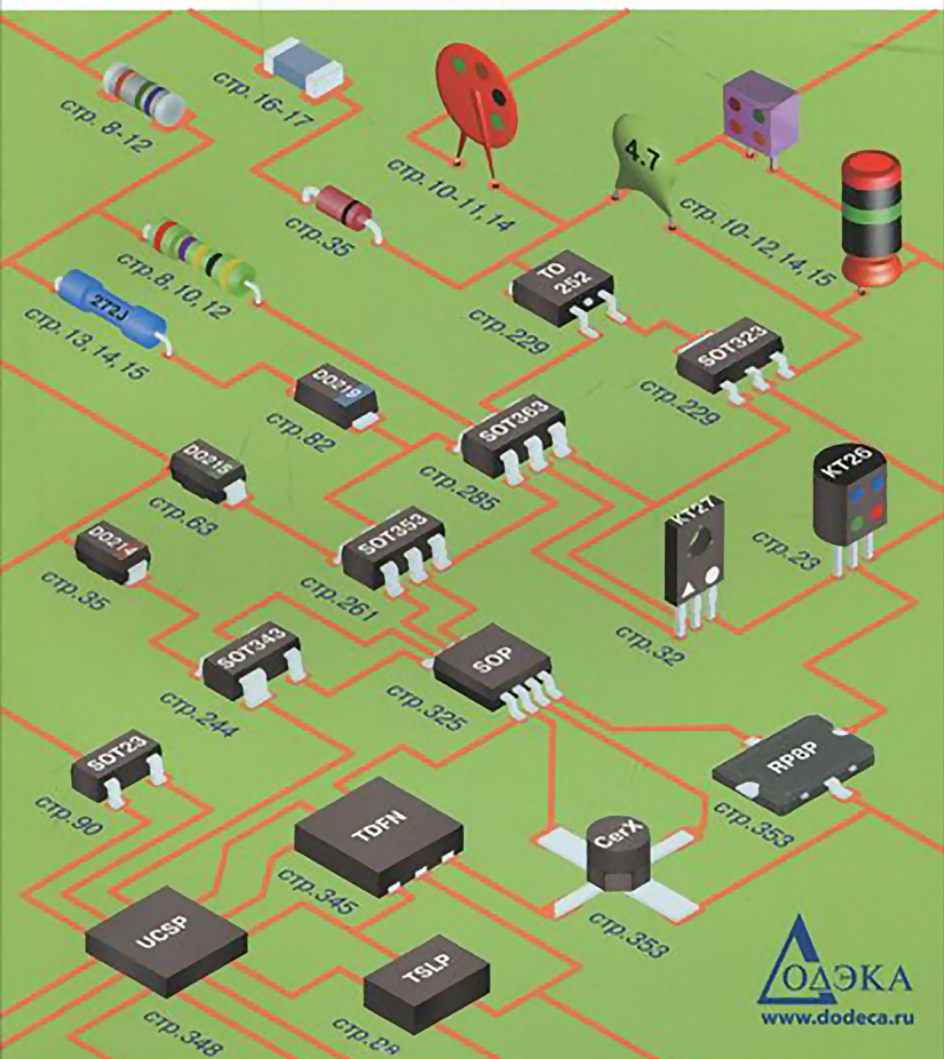


МАРКИРОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ



МАРКИРОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

*12-е издание
переработанное*



Издательский дом «Додэка-XXI»
Москва

УДК 621.382-777(035)
ББК 32.844-06-7я22+32. 852-06-7я22
M27

M27 Маркировка электронных компонентов. Определитель. — Изд. 12, перераб. —
М. : Додэка-XXI». — 386 с.

ISBN 978-5-94120-131-0

Книга представляет собой справочник-определитель электронных компонентов по их внешнему виду. Пользуясь данным справочником, можно расшифровать кодовую или цветовую маркировку большинства пассивных (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности) и активных (дискретные компоненты и микросхемы) электронных компонентов отечественного и импортного производства. Справочные материалы приведены в графической и табличной форме.

Поиск в определителе осуществляется по типу корпуса компонента, а далее по типу маркировки: цветовой или кодовой. Справочник содержит более 15000 кодовых маркировок активных компонентов: диодов, динисторов, стабилитронов, биполярных и полевых транзисторов, ключей, усилителей, компараторов, цифровых потенциометров, цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразователей, вентилялей и т.п. в корпусах для поверхностного монтажа, включая такие корпуса, как SOD, SOT, MSOP, TQFN, UCSP. На все компоненты приводится справочная информация о функциональном назначении приборов, фирме-производителя, основных характеристиках и особенностях, а также цоколевке выводов. В отдельных главах приведены подробные сведения по цветовой и кодовой маркировке отечественных компонентов в корпусах типа КТ-26 и КТ-27.

В главах, посвященных пассивным компонентам, рассмотрены принципы цветовой и кодовой маркировки резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности и других элементов по номиналу, допускам и другим параметрам, а также нестандартная маркировка компонентов некоторых ведущих фирм-производителей.

Книга предназначена для широкого круга радиолюбителей и радиоинженеров.

УДК 621.382-777(035.5)
ББК 32.844-06-7я22+32.852-06-7я22

Материалы подготовили
А. А. Бахметьев, В. Б. Ежов, И. С. Кирюхин, А. В. Перебаскин, В. М. Халикеев
Главный редактор *В. М. Халикеев*
Дизайн обложки *А. Ю. Анненков*
Иллюстрации *А. Ю. Анненков, И. Л. Люско*
Верстка *А. Ю. Анненков*

Издательский дом «Додэка-XXI»

105318 Москва, а/я 70
Тел/факс: (495) 366-24-29, 366-81-45
E-mail: books@dodeca.ru; red@dodeca.ru

Формат 70 x 100/32. Бумага офсетная. Гарнитура «PragmaticaC».
Печать офсетная. Объем 11,5 п. л. Тираж 3000 экз. Заказ № 829
Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Щербинская типография».
117623 Москва, ул. Типографская, д. 10. Тел. 659-23-27.

Все права защищены. Никакая часть этого издания не может быть воспроизведена в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотографирование, сканирование или иные средства копирования или сохранения информации без письменного разрешения издательства.

ISBN 978-5-94120-131-0

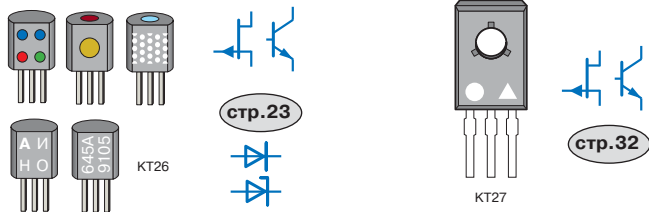
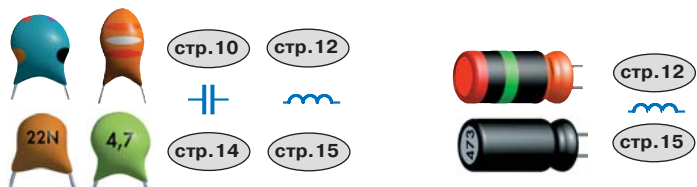
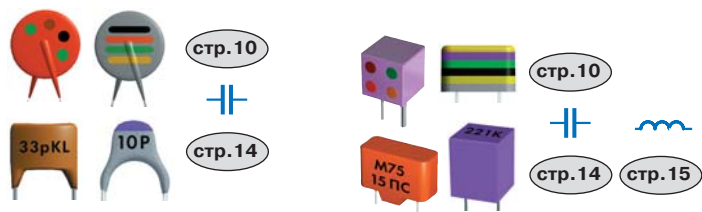
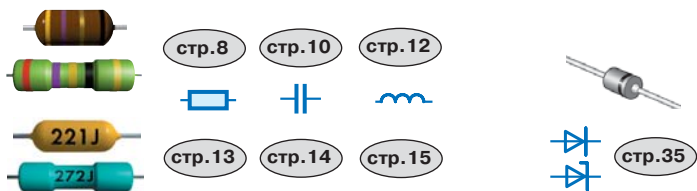
© Издательский дом «Додэка-XXI»

СОДЕРЖАНИЕ

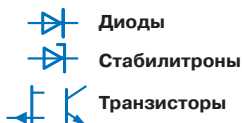
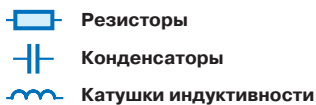
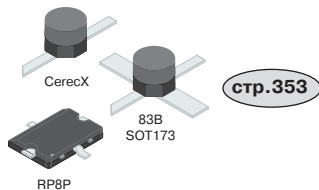
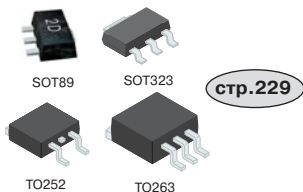
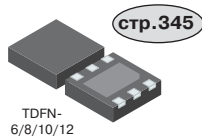
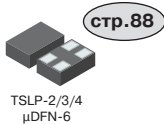
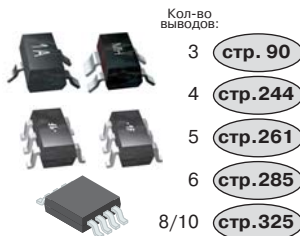
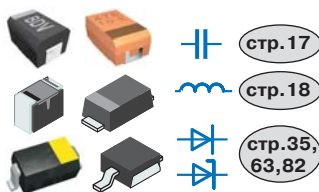
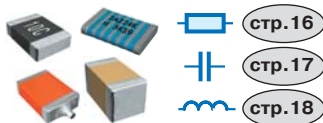
Навигатор по внешнему виду компонентов	4
Корпуса для монтажа в отверстия	4
Корпуса для поверхностного монтажа	5
Общие правила маркировки	6
Это необходимо знать	6
Цветовая маркировка пассивных компонентов	7
Символьная маркировка пассивных компонентов	7
Цифровая маркировка пассивных компонентов	7
Цветовая маркировка резисторов	8
Цветовая маркировка конденсаторов	10
Цветовая маркировка катушек индуктивности	12
Кодовая маркировка выводных резисторов	13
Кодовая маркировка выводных конденсаторов	14
Кодовая маркировка выводных катушек индуктивности	15
Маркировка резисторов для поверхностного монтажа	16
Маркировка конденсаторов для поверхностного монтажа	17
Маркировка индуктивностей для поверхностного монтажа	18
Таблицы соответствия	19
Ряды номинальных значений по EIA	21
Маркировка отечественных п/п приборов в корпусе КТ-26 (ТО-92)	22
История	22
Общие принципы маркировки	23
Типы маркировки полупроводниковых приборов	23
Цифро-буквенная маркировка	24
Цветовая четырехточечная маркировка	26
Символьно-цветовая маркировка	27
Цветовая двухточечная маркировка	29
Символьно-буквенная маркировка	30
Нестандартизируемая маркировка	31
Маркировка отечественных п/п приборов в корпусе КТ-27 (ТО-126)	32
Маркировка п/п компонентов для поверхностного монтажа	33
Назначение колонок в таблицах	33
SOD66/91	34
SOD110, DO214, SMA/B/C	35
SOD123/323, DO215/216	63
SOD523/623/723, DO219, SMF	82
SOT883, TSLP, μ DFN	88
SOT23-3, SOT323/523	90
SOT89/223, TO252/263	229
SOT143/343	244
SOT23-5, SOT353/553	261
SOT23-6, SOT363/563	285
MSOP/SOP-8/10	325
LFCSP, TDFN, TQFN	345
UCSP, WCSP	348
SOT173	353
Размеры корпусов для поверхностного монтажа	354
Список фирм-производителей	362
Список сокращений и условных обозначений	366
Список обозначений функции прибора	367
Таблица соответствия обозначений наиболее популярных корпусов	368

НАВИГАТОР ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ КОМПОНЕНТОВ

Корпуса для монтажа в отверстия



Корпуса для поверхностного монтажа



ОБЩИЕ ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ

Это необходимо знать

Для того чтобы правильно воспринимать и использовать материал, представленный в этой книге, необходимо ознакомиться со следующей информацией.

Очень важны размеры корпусов, поскольку внешне многие корпуса похожи друг на друга, а для идентификации прибора необходимо знать не только маркировку, но и тип корпуса. Но и это может не спасти. Так, корпус типа SOD-80 у фирмы Philips имеет диаметр 1.6 мм (ном.), а корпус с таким же названием у ряда других фирм имеет диаметр 1.4 мм, что даже меньше диаметра другого, более компактного, корпуса фирмы Philips SOD-80C. Корпус типа SOD-15 фирмы SGS-Thomson очень похож на корпуса 7043 и SMC, но не совпадает с ними по установочным размерам.

Возможны ситуации, когда фирмы-производители в одном и том же корпусе под одной и той же маркировкой выпускают разные приборы. Например, фирма Philips выпускает в корпусе SOT-323 *n-p-n*-транзистор BC818W и маркирует его кодом 6H, а фирма Motorola в таком же корпусе с той-же маркировкой 6H помещает *p-n-p*-транзистор MUN5131T1. Такая же ситуация встречается и внутри одной фирмы. Например, у фирмы Siemens в корпусе SOT-23 под маркировкой 1A выпускаются транзисторы BC846A и SMBT3904, имеющие разные параметры. Различить такие приборы, установленные на плате, можно только по окружающим их компонентам и, соответственно, схеме включения.

Путаница существует не только с маркировкой, но и цоколевкой корпусов. Например, корпус типа SOT-89 у фирм Rohm, Siemens, Toshiba имеет цоколевку 1-2-3 (вид сверху), а у Philips этот же корпус имеет цоколевку 2-3-1 или 3-2-1. В данной книге номера выводов и их функциональное значение у разных фирм приведены к единой системе.

Не лучше ситуация и с пассивными компонентами для поверхностного монтажа. Если на корпусе стоит маркировка 103, то это может быть резистор номиналом 10 кОм, конденсатор емкостью 10 нФ или индуктивность 10 мГн. Если на корпусе стоит маркировка 2R2, то это может быть и резистор номиналом 2.2 Ом, и конденсатор емкостью 2.2 пФ. Код 107 может означать 0.1 Ом (Philips) или 100 мкФ (Panasonic).

В корпусах типа 0603, 0805 и т.п. без маркировки могут находиться конденсатор, индуктивность или резистор-перемычка (Zero-Ohm jumper).

Цветная полоса или выемка-ключ на корпусах типа SOD-123, DO-215 может указывать на катод диода или вывод «плюс» у электролитического конденсатора.

По внешнему виду очень трудно отличить друг от друга R, C и L, если они находятся в цилиндрических корпусах с выводами и маркируются цветными кольцами. Но и после идентификации могут возникнуть сложности с определением параметров компонента. Например, на практике для цветовой маркировки постоянных конденсаторов используются несколько методик (см. главу «Конденсаторы. Цветовая маркировка»).

В одинаковых корпусах с одинаковым цветовым кодом может выпускаться целая серия приборов с разными параметрами. Например, фирма Motorola выпускает в корпусе типа SOD-80, маркируемом одним цветным кольцом, целую серию стабилитронов (51 прибор) с напряжением стабилизации от 1.8 до 100 В и током от 0.1 до 1.7 А. В таком же корпусе фирма Philips выпускает серию диодов.



SOD80



SOD15



7343



SMC



SOT323

BC818W
(Philips)

MVN5131T1
(Motorola)



SOT23

BC846A
(Siemens)

SMBT3904
(Siemens)



SOD123

Конденсатор — ⊕
Диод — катод
Стабилитрон — катод



R



L



C

Необходимо правильно определять сам цвет маркировки. На практике могут встречаться сложности с различием следующих оттенков: серый — св. голубой — серебристый; голубой — бирюзовый — электрик; желтый — золотистый; оранжевый — св. коричневый — табачный — бежевый.

Черное кольцо посередине корпуса имеют не только резисторы-перемычки (Zero-Ohm, jumper), но и другие приборы, особенно с учетом технологического разброса при нанесении маркировки.

Многие фирмы, помимо принципов маркировки, указанных в публикациях Международной Электротехнической Комиссии (IEC), используют свою внутрифирменную цветовую и кодовую маркировки. Например, встречается маркировка SMD-резисторов, когда вместо цифры 8 ставится двоеточие. В таких случаях маркировка 1:23 означает 182 кОм, а :0R6 — 80.6 Ом.

SOT (SOD) — Small Outline Transistor (Diode) — в дословном переводе означает «малогобаритный транзистор (диод)». На современном этапе в корпусе типа SOT помещают не только транзисторы и диоды, но и транзисторы с резисторами, стабилитроны, стабилизаторы напряжения на базе операционного усилителя и многое другое, а количество выводов может быть более трех. Органы стандартизации не успевают за новыми разработками фирм, и те вынуждены вводить свои новые обозначения, которые представлены в «Сводной таблице корпусов».

Цветовая маркировка пассивных компонентов

В соответствии с ГОСТ175-72 и требованиями Публикации 62 IEC цветовая маркировка наносится в виде 3, 4, 5 или 6 цветных колец. Маркировочные кольца должны быть сдвинуты к одному из выводов или ширина первого или второго кольца должна быть в два раза больше других, что на практике выдерживается не всегда. Вместо цветowych колец могут использоваться цветные точки.

При маркировке конденсаторов тремя кольцами допуск равен 20%; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на множитель. При маркировке пятью кольцами цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения. В полярных конденсаторах положительный вывод отмечается точкой или выводом большего диаметра.

Для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные.

Символьная маркировка пассивных компонентов

При символьной маркировке используются 2 или 3 цифры в сочетании с символом, расположенным на месте десятичной точки и обозначающим единицу измерения.

После номинала может указываться допуск и ТКЕ. Отсутствие маркировки допуска обычно означает допуск по умолчанию $\pm 20\%$. Для конденсаторов дополнительно может указываться рабочее напряжение, символьное обозначение которого обычно размещается в начале, перед номиналом.

Иногда применяется непосредственная маркировка номинала без указания множителя. В этом случае надпись «680K» на индуктивности будет означать не 68 мкГн $\pm 10\%$ (в соответствии со стандартной маркировкой), а 680 мкГн $\pm 10\%$.

Помимо вышеуказанных параметров на корпус может наноситься дополнительная кодированная информация, например о дате выпуска, типе, номинальной мощности и т.д.

Цифровая маркировка пассивных компонентов

При этом способе используются 3 или 4 цифры, последняя из которых обозначает количество нулей, добавляемых к стоящим впереди цифрам. Исключение составляют цифры 7, 8 и 9 для сопротивлений и цифра 9 для конденсаторов, обозначающие множитель в соответствии с приведенной ниже таблицей. Полученное значение равно номиналу в Ом для сопротивлений, пФ для емкости и мкГн для индуктивностей. Для электролитических конденсаторов номинальное значение обычно дается сразу в мкФ. При использовании 2 цифр номинальное значение берется из ряда E24 и имеет допуск 5% и более, при 3 цифрах номинальное значение берется из ряда E96 и имеет допуск 1% и менее.

Кроме стандартных способов маркировки используются и нестандартные, часть из которых приведена в примерах.

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ

3 метки ①—②—⊗ (допуск 20%)

ORA ORA ORA

33 кОм

4 метки ①—②—⊗—%

КОР ЧЕР ОРА ЖЕЛ

10 кОм ±5%

5 меток ①—②—③—⊗—%

ЖЕЛ ФИО ЧЕР ОРА КОР

470 кОм ±1%

ЖЕЛ ФИО ЧЕР КРА КРА

47 кОм ±2%

6 меток ①—②—③—⊗—%—ТК

КРА КРА ЧЕР КОР ФИО ОРА

2.2 кОм ±0.1%
±15 ppm/°C

	①	②	③	⊗	—	—	⊗	—	—	⊗	—	—	ТК
	Номинал			Множ.	Допуск	ТКС							
ЧЕР	0	0	1	±20%									
КОР	1	1	1	10	±1%	100							
КРА	2	2	2	10 ²	±2%	50							
ОРА	3	3	3	10 ³		15							
ЖЕЛ	4	4	4	10 ⁴		25							
ЗЕЛ	5	5	5	10 ⁵	±0.5%								
ГОЛ	6	6	6	10 ⁶	±0.25%	10							
ФИО	7	7	7	10 ⁷	±0.1%	5							
СЕР	8	8	8	10 ⁸	±0.05%	1							
БЕЛ	9	9	9										
ЗОЛ				0.1	±5%								
СРБ				0.01	±10%								

Нестандартная маркировка

Маркировка фирмы Corning Glass Work (CGW)

	10 кОм ±5%	Резисторы стандарта MILR22684
	220 кОм	Проволочные огнестойкие резисторы
	2.4 Ом ±5%	Проволочные резисторы промышленного применения

Маркировка фирмы Panasonic

	220 кОм ±1%	Металлооксидный пленочный резистор предохранитель
	220 кОм ±5000ppm/°C	Два цифровых кольца. Температурный коэфф-т (x100 ppm/°C)
	220 кОм	Огнестойкие резисторы типа AntiPulse
	220 кОм ±0.1%	Высококачественный пленочный резистор типа ERDAS3 для звуковой техники

Маркировка фирмы Philips

	2.7 МОм ±5%, VR	<p>(K) Цвет корпуса</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SFR — металлопленочные общего применения ■ NFR — металлопленочные резисторы-предохранители ■ MRS16 — металлопленочные прецизионные (5 полосок) ■ MRS25 — металлопленочные прецизионные (6 полосок) ■ PRO1/2 — металлопленочные мощные (1 Вт/2 Вт) ■ VR — толстопленочные высокоомные (>10 МОм), высоковольтные (>1 кВ)
	390 кОм ±10% MRS25, ±50 ppm/°C	

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА КОНДЕНСАТОРОВ

3 метки

1 ① ② ⊗

ORA ①
ZEL ②
KPA ⊗

3.9 нФ

① KPA ② FIO ③ ZEL

2.7 мкФ ±5%

2 ① ② ⊗

ZEL ①
CER ②
SEP ⊗

0.5 мкФ

4 метки

1 ① ② ⊗ %

ORA ①
CER ②
ZEL ③
KPA ④

3 мкФ ±2%

① KPA ② FIO ③ ZEL ④ ZOL

2.7 мкФ ±5%

KOR ①
ZEL ②
ORA ③
ZOL ④

15 нФ ±5%

① KPA ② KPA ③ ZEL ④ KPA

2.2 мкФ ±2%

2 ① ② ⊗ ⊕

ORA ①
CER ②
KOR ③
GOL ④

300 мкФ 20 В

1 ① ② ③ ⊗ % ⊕

Номинал Множ. Допуск ТКЕ

ЧЕР	0	0	0	1	±20%	NPO
КОР	1	1	1	10	±1%	N33
КРА	2	2	2	10 ²	±2%	N75
ОРА	3	3	3	10 ³		N150
ЖЕЛ	4	4	4	10 ⁴		N220
ЗЕЛ	5	5	5	10 ⁵		N330
ГОЛ	6	6	6	10 ⁶		N470
ФИО	7	7	7	10 ⁷		N750
СЕР	8	8	8	10 ⁸	±30%	Y5R
БЕЛ	9	9	9		-20...+80%	SL
ЗОЛ				0.1	±5%	
СРБ				0.01	±10%	Y5P

2 ① ② ⊗ ⊕

Номинал Множ. Напряж. (мкФ)

ЧЕР	0	0	1	10 В
КОР	1	1	10	
КРА	2	2	10 ²	
ОРА	3	3		
ЖЕЛ	4	4		6.3 В
ЗЕЛ	5	5		16 В
ГОЛ	6	6		20 В
ФИО	7	7		
СЕР	8	8	0.01	25 В
БЕЛ	9	9	0.1	3 В
РОЗ				35 В

4 метки

3 ①② ⊗ % U

5 меток

1 ① ② ⊗ % ТК

① ② ⊗ % ТК
КРА ФИО ЖЕЛ ЧЕР ЖЕЛ

0.27 мкФ ±20% -220ppm/°C

4 ① ② ⊗ % U

4.7 мкФ ±20% 400 В 0.015 мкФ ±10% 250 В

6 меток

1 ① ② ③ ⊗ % ТК

① ② ③ ⊗ % ТК
ОРА ЧЕР ОРА ЧЕР КРА

0.39 мкФ +80/-20% -75ppm/°C

3 ①② ⊗ % U

	Номинал	Множ.	Допуск	Напряж.
ЧЕР	10	1	±20%	4 В
КОР	12	10	±1%	6.3 В
КРА	15	10 ²	±2%	10 В
ОРА	18	10 ³	±0.25 нФ	16 В
ЖЕЛ	22	10 ⁴	0.5 нФ	40 В
ЗЕЛ	27	10 ⁵	±5%	20/25 В
ГОЛ	33	10 ⁶	±1%	30/32 В
ФИО	39	10 ⁷	-20...+50%	
СЕР	47	10 ⁻²	-20...+80%	3.2 В
БЕЛ	56	10 ⁻¹	±10%	63 В
СРБ	68			2.5 В
ЗОЛ	82		±5%	1.6 В

4 ①② ⊗ % U

	Номинал	Множ.	Допуск	Напряж.
КОР	1	0	ЧЕР	±10%
КОР	1	5	ЗЕЛ	±20%
КРА	2	2	КРА	250 В
ОРА	3	3	ОРА	10 ³
ЖЕЛ	2	2	ФИО	10 ⁴
ГОЛ	4	7	СЕР	10 ⁶
			БЕЛ	63 В
			ЧЕР	2.5 В
			ОРА	400 В
			ЖЕЛ	40 В
			ЗЕЛ	20/25 В

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ

3 метки ① ② ⊗ (допуск 20%)

① ② ⊗
КРА ЗЕЛ ОРА



25 мГн ±20%


① ② ⊗
ЖЕЛ ФИО ЧЕР



47 мГн ±20%

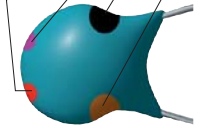
4 метки ① ② ⊗ %

① ② ⊗ %
ЖЕЛ ФИО ЗОЛ ЧЕР




4.7 мкГн ±20%

① ② ⊗ %
КРА ФИО ЧЕР ЗОЛ



27 мГн ±5%

① ② ⊗ %
КРА КРА ЧЕР СРБ



22 мкГн ±10%

① ② ⊗ %
 Номинал Множ. Допуск

	0	1	±20%
ЧЕР	1	1	10
КОР	2	2	10 ²
КРА	3	3	10 ³
ОРА	4	4	
ЖЕЛ	5	5	
ЗЕЛ	6	6	
ГОЛ	7	7	
ФИО	8	8	
СЕР	9	9	
БЕЛ	0.1		±5%
ЗОЛ	0.01		±10%
СРБ			

КОДОВАЯ МАРКИРОВКА ВЫВОДНЫХ РЕЗИСТОРОВ

НОМИНАЛ [Ом]		ДОПУСК (%)	
① ② ③	Базовое значение из рядов E3, E6, E12, E24, E48, E96, E192	МЭК 62	СТ СЭВ 1810-79
	Множитель как десятичная запятая		ГОСТ 11076-69
ⓔ	R(E) = Ом K(K) = кОм (10^3 Ом) M(M) = МОм (10^6 Ом) G(G) = ГОм (10^9 Ом) T(T) = ТОм (10^{12} Ом)		Допуск [%]
		E	E
		L	L
		R	R
		P	P
		U	U
		A	X
		B	B
		C	C
		D	D
		F	F
		G	G
		J	J, I
		K	K
		M	M
		N	N
			Ж
			У
			Д
			Р
			Л
			И
			С
			В
			Ф



533M	или	E33M	= 0.33 Ом ±20%
4R7F	или	4E7F	= 4.7 Ом ±1%
330RG	или	K33G	= 330 Ом ±2%
110KD	или	M10D	= 110 кОм ±0.5%
220MN	или	G22N	= 220 МОм ±30%
1M1M			= 1.1 МОм ±30%
12GK			= 12 ГОм ±10%

Презиционные резисторы фирмы **Panasonic**

① ② ③ X % TK

10 кОм ±1%
±50ppm/°C

Тип резистора **55**

TK

ⓔ ① ② ③ %

1 кОм ±0.1%
±5ppm/°C

Тип резистора **ERNSB**

TK


TK [ppm/°C]

ⓔ ±25 5 ±5
C ±50
D ±100

Перемычки керамика-металл (R < 13 МОм)


КОДОВАЯ МАРКИРОВКА ВЫВОДНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ

1 ① ② × %




473K

47 нФ ±10%



682M

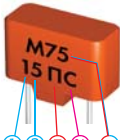
6.8 нФ ±20%



221J


220 пФ ±5%

2 ① ② E % ТК



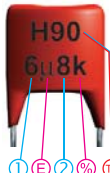
**M75
15 пФ**

15 пФ ±0.25%
-75 ppm/°C



33pKL


33 пФ ±0.10%
-75 ppm/°C



**H90
6.8 мкФ**

6.8 мкФ ±0.10%
TKE ±90%


3 ① ② ③ × %



D1622K

16.2 нФ ±10%, 20 В


4 ① ② ③



**.02
10**

Маркировка в мкФ
0.02 мкФ
10 В

5 ① ② E ТК



10P

Смешанная маркировка
10 пФ
750 ppm/°C

**Напря-
жение**
[В]

①
G 4
J 6.3/7
A 10
C 16
D 20
E 25
V 35

Номинал

Вариант 1:

① ② ③ E
 2 или 3 цифры
 и буква как де-
 сятичная точка
 и единица изм.:
 E E
 R П пФ
 P, p пФ
 n H нФ
 m, μ мкФ

Вариант 2:

① ② ③ ×
 3 или 4 цифры,
 последняя из
 которых равна
 числу добавочных
 нулей, кроме:
 9 = × 0.1
 Единица
 измерения:
 пФ

Допуск [%]

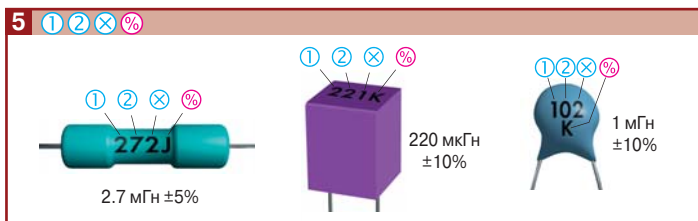
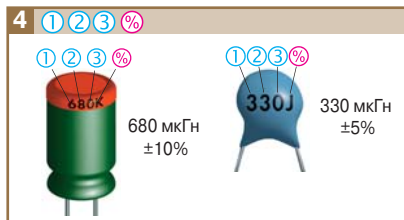
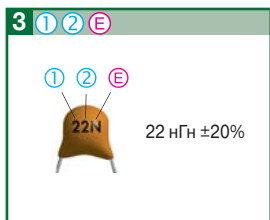
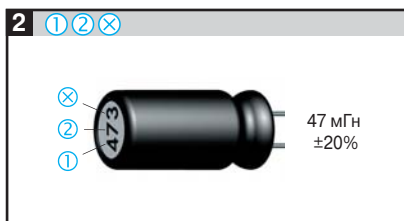
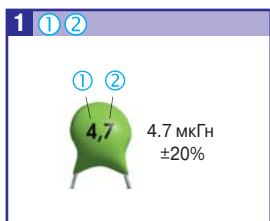
① ②
B Ж ±0.1
C Y ±0.25
D D ±0.5
F P ±1
G L ±2
J J ±5
K C ±10
M B ±20
N V ±30
Q O -10...+30
T Э -10...+50
Y Ю -10...+100
S Б -20...+50
Z А -20...+80

TKE [ppm/°C]

① ②
A П100
B Н10
C МП0
D Н30
E Н70
F Н90
H М33
K М2200
L М75
N П33
P М150
R М220
S П330
T М470
U М750
V М1500
X Н50
Z Н20

► 14

КОДОВАЯ МАРКИРОВКА ВЫВОДНЫХ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ



Номинал

Вариант 1:



2 цифры и буква как десятичная точка и ед. изм. E мкГн R нГн N

Вариант 2:



3 цифры, последняя из которых равна числу доб. нулей. Ед. изм. мкГн

Вариант 3:



3 цифры. Единица изм. мкГн

Допуск



J ±0.3 нГн
K ±5 %
M ±10 %
N ±20 %

МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

XXX



допуск 1%,
размер 0603



12.4 кОм



Множитель:

S — 10^{-2} **C** — 10^{-2}

R — 10^{-1} **D** — 10^{-3}

A — 1 **E** — 10^4

B — 10 **F** — 10^5

①②

Номер номинального значения из ряда E96:

01 — 100	21 — 162	41 — 261	61 — 422	81 — 681
02 — 102	22 — 165	42 — 267	62 — 432	82 — 698
03 — 105	23 — 169	43 — 274	63 — 442	83 — 715
04 — 107	24 — 174	44 — 280	64 — 453	84 — 732
05 — 110	25 — 178	45 — 287	65 — 464	85 — 750
06 — 113	26 — 182	46 — 294	66 — 475	86 — 768
07 — 115	27 — 187	47 — 301	67 — 487	87 — 787
08 — 118	28 — 191	48 — 309	68 — 499	88 — 806
09 — 121	29 — 196	49 — 316	69 — 511	89 — 825
10 — 124	30 — 200	50 — 324	70 — 523	90 — 845
11 — 127	31 — 205	51 — 332	71 — 536	91 — 866
12 — 130	32 — 210	52 — 340	72 — 549	92 — 887
13 — 133	33 — 215	53 — 348	73 — 562	93 — 909
14 — 137	34 — 221	54 — 357	74 — 576	94 — 931
15 — 140	35 — 226	55 — 365	75 — 590	95 — 953
16 — 143	36 — 232	56 — 374	76 — 604	96 — 976
17 — 147	37 — 237	57 — 383	77 — 619	
18 — 150	38 — 243	58 — 392	78 — 634	
19 — 154	39 — 249	59 — 402	79 — 649	
20 — 158	40 — 255	60 — 412	80 — 665	

XXX



1 Ом

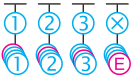


33 кОм



10 МОм

XXXX



42.2 кОм



0.47 Ом

①②③ Номинал [Ом]:

0...9

⊗ Множитель:

1 — 10^0

4 — 10^4

7 — 10^{-2}

2 — 10^2

5 — 10^5

8 — 10^{-1}

3 — 10^3

6 — 10^6

9 — 10^0

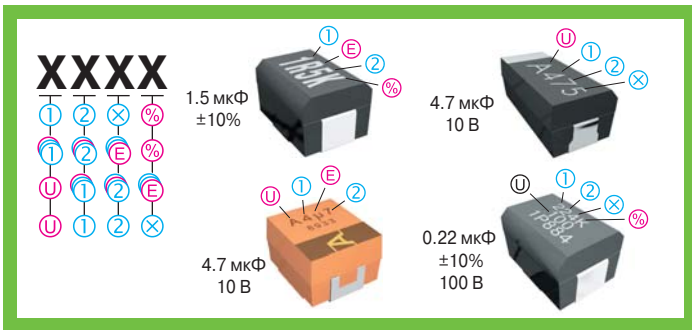
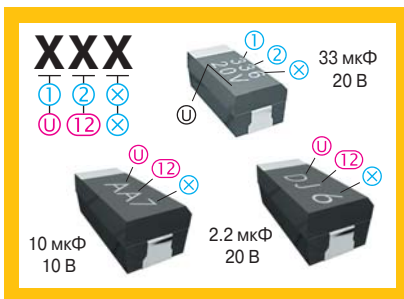
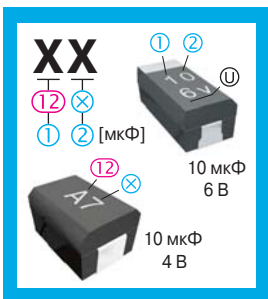
ⓔ Десятичная

точка: **R**

**Перемиčky
(Jumper-Chip)
R < 50 МОм**



МАРКИРОВКА КОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА



Ⓚ Рабочее напряжение:

G — 4
J — 6.3/7 **D** — 20
A — 10 **E** — 25
C — 16 **V** — 35

Ⓚ Рабочее напряжение:

0...9 — величина
V — вольты

Ⓚ Номинал [пф]:

A — 1.0	M — 3.0	Z — 8.2
B — 1.1	N — 3.3	Y — 9.1
C — 1.2	P — 3.6	a — 2.5
D — 1.3	Q — 3.9	b — 3.5
E — 1.5	R — 4.3	d — 4.0
F — 1.6	S — 4.7	e — 4.5
G — 1.8	T — 5.1	f — 5.0
H — 2.0	U — 5.6	m — 6.0
J — 2.2	V — 6.2	n — 7.0
K — 2.4	W — 6.8	t — 8.0
L — 2.7	X — 7.5	g — 9.0

Ⓚ Множитель:

9 — 0.1
0 — 1
1 — 10
2 — 10²
3 — 10³
4 — 10⁴
5 — 10⁵
6 — 10⁶
7 — 10⁷

Ⓚ Десятичная точка и единица измерения:
μ — мкФ **R** — мкФ

Ⓚ Номинал:
 (ⓀⓀⓀ) — [пф]
0...9

Ⓚ Допуск [%]:
J — ±5,
K — ±10,
M — ±20

Маркировка конденсаторов для поверхностного монтажа

XXXXXX

D U 1 2 X %

T

Температура пайки:

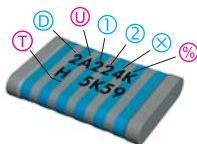
G — 250°C/5 с

H — 260°C/5 с

J — 260°C/10 с

D

Диапазон рабочего напряжения:
 0 — <10 В
 1 — <100 В
 2 — <1000 В



0.22 мкФ ±10% 100 В

МАРКИРОВКА ИНДУКТИВНОСТЕЙ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

XXX

1 2 X
 1 2 E

Допуск ±20%

XXXX

1 2 X %
 1 2 E %



0.68 мкГн ±20%

Номинал

Вариант 1:

1 2 E

2 цифры и буква как десятичная точка и ед. изм.

E

R мкГн
 N нГн

Вариант 2:

1 2 X

3 цифры, последняя из которых равна числу доб. нулей. Ед. изм. мкГн

Вариант 3:

1 2 3

3 цифры. Единица изм. мкГн

Допуск

%

D ±0.3 нГн
 J ±5 %
 K ±10 %
 M ±20 %

ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ

Ниже приведены таблицы соответствия между параметрами и их обозначением с помощью цвета, символов и цифр. Для названий цвета используются следующие сокращения: чер — черный, кор — коричневый, кра — красный, т-кра — темно-красный, ора — оранжевый, жел — желтый, зел — зеленый, т-зел — темно-зеленый, гол — голубой, син — синий, фио — фиолетовый, сер — серый, бел — белый, зол — золотой, срб — серебрянный, роз — розовый, беж — бежевый, сал — салатный, таб — табачный, бир — бирюзовый, эле — электрик.

Н ① ② ③ Маркировка номинального значения

Единица измерения: сопротивление — Ом, емкости — пФ, индуктивности — мкГн

Значение	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цветовая маркировка	 чер	 кор	 кра	 ора	 жел	 зел	 гол	 фио	 сер	 бел
Цифровая марк.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

⊗ Маркировка множителя



















Значение	0.01	0.1	1	10	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁸	10 ⁹
Цветовая маркировка	 срб	 зол	 чер	 кор	 кра	 ора	 жел	 зел	 гол	 фио	 сер	 бел
Цифровая маркировка	R	7	8	9	1	2	3	4	5	6		
	C		9	0	1	2	3	4	5	6	7	8

Е Маркировка единицы измерения

Положение символа указывает на положение десятичной точки

Значение	Сопротивления					Емкости			Индуктивности	
	Ом	кОм	МОм	ГОм	ТОм	пФ	нФ	мкФ	нГн	мкГн
Сим-вол	R	K	M	G	T	R,P	n	m,μ	N	R
рус.	Е	К	М	Г	Т	П	н	м,μ	Н	Р

⊘ Маркировка допуска

Значение [%]	±0.001	±0.002	±0.005	±0.01	±0.02	±0.05	±0.1	±0.25	±0.5	±1	±2	±5	±10	±20	±30	-10+30	-10+50	-10+100	-20+50	-20+80	
Цветовая маркировка	R					 сер	 фио	 гол	 зел	 кор	 кра	 зол	 срб								
	C L							 ора	 жел	 кор	 кра	 зол	 срб	 чер	 сер				 фио	 сер	
Сим-вол:	межд. рус.	E	L	R	P	U	A	B Ж*	C У*	D Д*	F Р*	G Л	J И	K С	M В	N Ф	Q О	T Э	Y Ю	S Б	Z А

* Для конденсаторов емкостью < 10 пФ допуск имеет размерность пикофард.
Для индуктивности используются допуски ±5%, ±10% и ±20%, символ D = ±0.3 нГн

ⓧ Маркировка температурного коэффициента сопротивлений

Значение	1	5	10	15	25	50	100
Цвет	 сер	 фио	 гол	 ора	 жел	 кра	 кор
Символ (межд.)					E	C	D

Таблицы соответствия

ТК Маркировка ненормируемого температурного коэффициента емкости

Группа	H10	H20	H30	H50	H70	H90
Допуск в диапазоне -60...+85°C	±10%	±20%	±30%	±50%	±70%	±90%
Цвет*	ора+чер	ора+кра	ора+зел	ора+гол	ора+фио	ора+бел
Символ (межд.)	B	Z	D	X	E	F

* Современная цветовая кодировка. Цветные полосы или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.

ТК Маркировка линейного температурного коэффициента емкости

Группа	межд. рус.	P100	П33	NP0	N030	N080	N150	N220	N330	N470	N750	N1500	N2200
		П100	М33	МР0	M33	M75	M150	M220	M330	M470	M750	M1500	M2200
ТКЕ [ppm/°C]		100	33	0	-33	-75	-150	-220	-330	-470	-750	-1500	-2200
Разброс*		-49 ...+130		-75 ...+30	-80 ...+30	-80 ...+30	-105 ...+30	-120 ...+30	-180 ...+60	-210 ...+60	-330 ...+120	-670 ...+250	
Цвет**		кра+фио	сер	чер	кор	кра	ора	жел	зел	гол	фио	ора+ора	жел+ора
Символ (межд.)		A	N	C	H	L	P	R	S	T	U	V	K

* Реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур -55...+85°C.

** Современная цветовая кодировка в соответствии с EIA. Цветные полосы или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.

ТК Маркировка нелинейного температурного коэффициента емкости

Обозначения групп приведены в соответствии со стандартом EIA, в скобках указан стандарт IEC. Маркировка дана в соответствии с EIA. Некоторые фирмы, например Panasonic, используют другой кодировкой.

	Допуск						
	±7.5%	±10%	±15%	±22%	+22...-56%	+22...-82%	+150...-1500%
* -10...+85°C	Z5F B	Z5P: C		Z5S	Z5U (2E): E	Z5V: F ,	
-30...+85°C	Y5F	Y5P:	Y5R: R ,	Y5S: S ,	Y5U: A	Y5V (2F)	
-55...+85°C	X5F	X5P		X5S	X5U:	X5V	
-55...+125°C			X7R (2R)				
-55...+150°C							SLO (GP): Nil ,

* В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон может быть другим. Например, фирма Philips для группы Y5P нормирует -55...+125 °C.

U Маркировка рабочего напряжения емкостей

Значение [В]	2.5	3	4	6.3/7	10	16	20	25	35	50	63	100	250	400	630
Код (межд.)	0E,E		0G,G	0J,J	1A,A	1C,C	1D,D	1E,V	1V,V	1H	1J	2A	2E	2G	2J

РЯДЫ НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ЕІА

Допуски: E3 — 50%, E6 — 20%, E12 — 10%, E24 — 5%, E48 — 2%, E96 — 1%, E192 — < 0.5%

Не использ.	E3	100	220						470						
Редко исп.	E6	100	150	220			330			470			680		
	E12	100	120	150	180	220	270	330	390	470	560	680	820		
	E24	100	120	150	180	220	270	330	390	470	560	680	820		
		110	130	160	200	240	300	360	430	510	620	750	910		

E48	E96	E192	E48	E96	E192	E48	E96	E192	E48	E96	E192	E48	E96	E192	E48	E96	E192
100	100	100	147	147	147	215	215	215	316	316	316	464	464	464	681	681	681
		101			149			218			320			470			690
	102	102		150	150		221	221		324	324		475	475		698	698
		104			152			223			328			481			706
105	105	105	154	154	154	226	226	226	332	332	332	487	487	487	715	715	715
		106			156			229			336			493			723
	107	107		158	158		232	232		340	340		499	499		732	732
		109			160			234			344			505			741
110	110	110	162	162	162	237	237	237	348	348	348	511	511	511	750	750	750
		111			164			240			352			517			759
	113	113		165	165		243	243		357	357		523	523		768	768
		114			167			246			361			530			777
115	115	115	169	169	169	249	249	249	365	365	365	536	536	536	787	787	787
		117			172			252			370			542			796
	118	118		174	174		255	255		374	374		549	549		806	806
		120			176			258			379			556			816
121	121	121	178	178	178	261	261	261	383	383	383	562	562	562	825	825	825
		123			180			264			388			569			835
	124	124		182	182		267	267		392	392		576	576		845	845
		126			184			271			397			583			856
127	127	127	187	187	187	274	274	274	402	402	402	590	590	590	866	866	866
		129			189			277			407			597			876
	130	130		191	191		280	280		412	412		604	604		887	887
		132			193			284			417			612			898
133	133	133	196	196	196	287	287	287	422	422	422	619	619	619	909	909	909
		135			198			291			427			626			920
	137	137		200	200		294	294		432	432		634	634		931	931
		138			203			298			437			642			942
140	140	140	205	205	205	301	301	301	442	442	442	649	649	649	953	953	953
		142			208			305			448			657			965
	143	143		210	210		309	309		453	453		665	665		976	976
		145			213			312			459			673			988

МАРКИРОВКА ОТЧЕСТВЕННЫХ П/П ПРИБОРОВ В КОРПУСЕ КТ-26 (ТО-92)

Нет, не удалось нам догнать буржуев нигде, кроме как в области цветовой и кодовой маркировки радиокомпонентов. Здесь мы не только догнали загнивающий Запад, но и перегнали его, как говорится, «навсегда». Никакому иностранцу никогда не удастся расшифровать таинственные и постоянно меняющиеся комбинации странных значков и таинственных точек, коими маркируются отечественные полупроводниковые приборы. Что, в общем-то, хорошо: чего не понимают, того хотя бы опасаются, так что можно считать отечественную маркировку частью нашей оборонной инициативы, как говорится, «наш ответ на ультиматум Керзона». Но в своей страсти зашифровать и засекретить все и вся мы зашли слишком далеко, так как и собственное население уже не может понять, что же за загадочные приборы впаивая в наши неказистые платы.

Невозможно объять необъятное, поэтому из всей массы приборов мы постарались выбрать группу, которая наиболее часто маркируется всевозможными кодами. Понятно, что применение кодовой маркировки связано в первую очередь с размерами, а значит, и типом корпуса. Безусловным лидером по частоте применения кодовой маркировки является корпус типа КТ-26. Выпускавшийся ранее корпус КТП-4 представляет собой модификацию КТ-26 и, следовательно, тоже попадает под рассмотрение. В связи с вышеизложенным, упор, сделанный в данном издании на маркировку полупроводниковых приборов, выпускающихся в корпусе КТ-26, является закономерным и позволяет ответить на большинство вопросов, связанных с кодовой маркировкой.

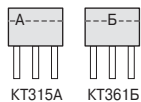
Первый и самый неутешительный вывод, полученный в результате исследований: по маркировке полупроводниковых приборов, выпускающихся в корпусе КТ-26, часто НЕВОЗМОЖНО однозначно установить тип прибора. Можно долго рассуждать, почему так случилось и кто в этом виноват; мы же считаем, что сложившаяся ситуация является, результатом во-первых, нашего российского менталитета, то есть привычкой решать все проблемы административным путем, а во-вторых, особенностей протекания исторического процесса в нашей стране. Из последнего утверждения следует очень важный вывод: маркировка полупроводниковых приборов, выпускающихся в корпусе КТ-26, есть категория историческая. Это значит, в частности, что если производитель какого-нибудь транзистора в 1992 году маркировал его, допустим, красной точкой, а в 1993 году перестал выпускать этот транзистор, то в 1994 году мог появиться другой (а иногда и тот же самый) производитель и замаркировать красной точкой совершенно другой прибор, считая, что данная конкретная маркировка «свободна».

Вообще-то, служение полупроводниковой промышленности в советское время нуждам военно-промышленного комплекса не пошло ей на пользу. До сих пор принципы маркировки компонентов их изготовитель считает исключительно своей прерогативой и руководствуется в них даже не ГОСТами, а своими сиюминутными интересами, как-то: наличием или отсутствием необходимой краски, трудностями, связанными с изготовлением клейма, и т.п. Выполнение требований по маркировке, внесенных в ТУ, обходят обычно следующим образом: достаточно крупные партии приборов выпускаются «по нормам главного конструктора» или «по конкретному контракту», что позволяет маркировать эти партии так, как удобно изготовителю. Еще «хлеще» маркируются приборы, выпускаемые в странах СНГ для российского рынка. Самостоятельно, видимо, не позволяет маркировать по российским стандартам, а свои выработать просто некогда, да и некому, надо быстрее клепать приборы, а то скоро эту «высокотехнологичную продукцию» никто брать не будет. Исключения в лучшую сторону достаточно редки и серьезного исследователя интересовать не могут.

История

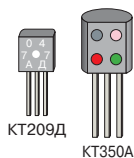
Первым массовым транзистором с кодовой маркировкой был КТ315 в миниатюрном пластмассовом корпусе КТ-13. На нем в левом верхнем углу плоской стороны ставилась буква, обозначающая группу, ниже иногда указывалась дата изготовления. Через несколько лет в корпусе КТ-13 стали выпускать транзистор прямой проводимости — КТ361. Для отличия от КТ315 буква, обозначающая группу, ставилась посередине верхней части плоской стороны.

В 1974 году появился транзистор КТ375 в корпусе КТ-26 (тогда еще с круглыми выводами), который маркировался цифрами 375 и буквой, указывающей группу транзистора.



Маркировка отечественных п/п приборов в корпусе КТ-26 (ТО-92)

В 1976 году появляется целая группа транзисторов в корпусах КТП-4 и КТ-26, отмаркированных цветовым четырехточечным кодом, и транзистор КТ209 (корпус КТП-4), который маркировался буквой А в левом нижнем углу плоской стороны корпуса. В правом нижнем углу плоской стороны корпуса буквой указывалась группа прибора, выше — двумя цифрами год, а еще выше — двумя цифрами дата изготовления. Понять, что это за приборы, без расшифровки кода было уже невозможно, поэтому 1976 год можно считать началом эры цветовой и кодовой маркировки корпуса КТ-26 в СССР.



В 1979 году появляются транзисторы в корпусе КТ-26, маркированные символами. Сначала символы ставятся где попало, но к 1985 году они обретают постоянное место в левом верхнем углу плоской стороны корпуса. Примерно в это же время появляются транзисторы, маркируемые двумя цветовыми метками. С 1988 года набирает обороты сокращенная символическая маркировка.

Общие принципы маркировки

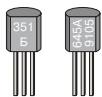
Корпус КТ-26 (ТО-92) изготавливается из пластмассы темного, чаще черного, цвета, поэтому все надписи наносятся белой или серебристой краской. Маркировка обычно наносится на срезе боковой поверхности корпуса, реже — на цилиндрической части боковой поверхности корпуса, на торце корпуса цветовым кодом указывают группу прибора.

Встречаются приборы, торец корпуса которых целиком покрашен каким-либо цветом. Это, за немногими исключениями, внутривзаводская маркировка, которая, как правило, не стандартизируется и не расшифровывается (обозначает иногда разбраковку по одному или нескольким параметрам: номер смены и т.п.). Уловить какие-нибудь закономерности здесь не удалось, да и не очень надо, так как для массового потребителя данный тип маркировки несет немного полезной информации.

На корпусе стараются указать тип прибора, группу, дату выпуска (год, месяц или номер смены). Наиболее важными представляются тип и группа прибора — на них мы и сосредоточим свое внимание; что касается даты изготовления, то часто она вообще не указывается. Когда же дата указывается, чаще всего это делается согласно ГОСТ 25486-82 (см. раздел Символьно-буквенная маркировка) или просто: двумя цифрами год, двумя (одной) месяц (например, 95 09 означает 1995 год, сентябрь-месяц). Встречается обратный порядок указания года и месяца (например, 3-74 означает март 1974 года) или обозначение только года изготовления двумя цифрами (например, 85 — 1985 год).

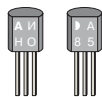
Типы маркировки полупроводниковых приборов

Для удобства все рассмотренные варианты маркировки полупроводниковых приборов, выпускающихся в корпусе КТ-26, были разбиты на шесть классов, которым были присвоены условные названия:



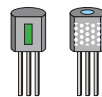
КТ351Б КТ645А

Цифро-буквенная маркировка



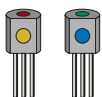
КП364И КТ502А

Символьно-буквенная маркировка



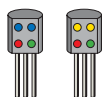
КП501А КТ3107А

Символьно-цветовая маркировка



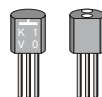
КП364А КТ342ВМ

Цветовая двухточечная маркировка



КТ349В КТ351Б

Цветовая четырехточечная маркировка



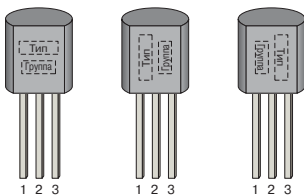
КП103Е КТ325АМ

Нестандартизуемая маркировка

Маркировка отечественных п/п приборов в корпусе КТ-26 (ТО-92)




Цифро-буквенная маркировка

Цифро-буквенная маркировка может быть полной и сокращенной. Наносится на срез боковой поверхности корпуса, как правило, в две строки друг над другом, возможны как правый поворот надписи, так и левый, а также маркировка в одну строку. Исходно полный список сокращенного варианта цифро-буквенной маркировки приведен ниже в таблице (используемые условные обозначения расшифрованы в списке сокращений). Приборы, тип и группа которых промаркированы полностью, по понятным причинам в данном издании не рассматриваются.



Тип	Функция	1-2-3	Маркировка	Тип	Функция	1-2-3	Маркировка	Тип	Функция	1-2-3	Маркировка
КТ969А1	р-п-п	Е-С-В	1А	КТ307Е1	п-FET	G-D-S	307Е	КТ349В	р-п-р	С-В-Е	349В
КР1188ЕН5	рег+	I-C-O	8ЕН5	КТ307Ж1	п-FET	G-D-S	307Ж	КТ350А	р-п-р	С-В-Е	350А
КР1188ЕН8	рег+	I-C-O	8ЕН8	КТ313А1	р-п-р	С-В-Е	313А1	КТ351А	р-п-р	С-В-Е	351А
КР1188ЕН9	рег+	I-C-O	8ЕН9	КТ313А2	р-п-р	Е-С-В	313А2	КТ351Б	р-п-р	С-В-Е	351Б
КР1188ЕН12	рег+	I-C-O	8ЕН12	КТ313Б1	р-п-р	С-В-Е	313Б1	КТ352А	р-п-р	С-В-Е	352А
КТ117АМ	О	Е-В1-В2	17А	КТ313Б2	р-п-р	Е-С-В	313Б2	КТ352Б	р-п-р	С-В-Е	352Б
КТ117БМ	О	Е-В1-В2	17Б	КТ313В1	р-п-р	С-В-Е	313В1	КТ355АМ	п-п-п	С-В-Е	355А
КТ117ВМ	О	Е-В1-В2	17В	КТ313В2	р-п-р	Е-С-В	313В2	КТ357В	р-п-р	С-В-Е	357А
КТ117ГМ	О	Е-В1-В2	17Г	КТ313Г1	р-п-р	С-В-Е	313Г1	КТ357А	р-п-р	С-В-Е	357Б
КР1157ЕН1	рег+	С-О-I	57ЕН	КТ313Г2	р-п-р	Е-С-В	313Г2	КТ357Б	р-п-р	С-В-Е	357В
КР1168ЕН1	рег+	С-О-I	68ЕН1	КТ3157А	р-п-р	С-Е-В	3157А	КТ361А2	р-п-р	Е-С-В	361А2
КР142ЕН17А	рег+	О-С-I	69	КТ315А1	п-п-п	Е-С-В	315А1	КТ361А3	р-п-р	Е-С-В	361А3
КР142ЕН17Б	рег+	О-С-I	70	КТ315Б1	п-п-п	Е-С-В	315Б1	КТ361Б2	р-п-р	Е-С-В	361Б2
КР142ЕН19	рег+	G-A-K	71	КТ315В1	п-п-п	Е-С-В	315В1	КТ361В2	р-п-р	Е-С-В	361В2
КТ133А	О	В1-Е-В2	133А	КТ315Г1	п-п-п	Е-С-В	315Г1	КТ361Г2	р-п-р	Е-С-В	361Г2
КТ133Б	О	В1-Е-В2	133Б	КТ315Д1	п-п-п	Е-С-В	315Д1	КТ361Г3	р-п-р	Е-С-В	361Г3
КР1125КП3А	bid	К-А1-А2	153А	КТ315Е1	п-п-п	Е-С-В	315Е1	КТ361Д2	р-п-р	Е-С-В	361Д2
КР1125КП3Б	bid	К-А1-А2	153Б	КТ315Ж1	п-п-п	Е-С-В	315Ж1	КТ361Д3	р-п-р	Е-С-В	361Д3
КР1125КП3В	bid	К-А1-А2	153В	КТ315И1	п-п-п	Е-С-В	315И1	КТ361Е2	р-п-р	Е-С-В	361Е2
КТ208А1	р-п-р	С-В-Е	208А	КТ315Н1	п-п-п	Е-С-В	315Н1	КТ361Ж2	р-п-р	Е-С-В	361Ж2
КТ208Б1	р-п-р	С-В-Е	208Б	КТ315Р1	п-п-п	Е-С-В	315Р1	КТ361И2	р-п-р	Е-С-В	361И2
КТ208В1	р-п-р	С-В-Е	208В	КТ316АМ	п-п-п	С-В-Е	316А(М)	КТ361К2	р-п-р	Е-С-В	361К2
КТ209А	р-п-р	С-В-Е	209А	КТ316БМ	п-п-п	С-В-Е	316Б(М)	КТ361Л2	р-п-р	Е-С-В	361Л2
КТ209Б	р-п-р	С-В-Е	209Б	КТ316ВМ	п-п-п	С-В-Е	316В(М)	КТ361М2	р-п-р	Е-С-В	361М2
КТ209Б1	р-п-р	С-В-Е	209Б1	КТ316ГМ	п-п-п	С-В-Е	316Г(М)	КТ361Н2	р-п-р	Е-С-В	361Н2
КТ209В	р-п-р	С-В-Е	209В	КТ316ДМ	п-п-п	С-В-Е	316Д(М)	КТ361П2	р-п-р	Е-С-В	361П2
КТ209Б1	р-п-р	С-В-Е	209Б1	КТ325АМ	п-п-п	С-Е-В	325А	КТ363АМ	р-п-р	С-В-Е	363АМ
КТ209В2	р-п-р	С-В-Е	209В2	КТ325БМ	п-п-п	С-Е-В	325Б	КТ363БМ	р-п-р	С-В-Е	363БМ
КТ209Г	р-п-р	С-В-Е	209Г	КТ325ВМ	п-п-п	С-Е-В	325В	КТ364А	nFET	G-D-S	364А
КТ209Д	р-п-р	С-В-Е	209Д	КТ326АМ	р-п-р	С-В-Е	326АМ	КТ364Б	nFET	G-D-S	364Б
КТ209Е	р-п-р	С-В-Е	209Е	КТ326БМ	р-п-р	С-В-Е	326БМ	КТ364В	nFET	G-D-S	364В
КТ209Ж	р-п-р	С-В-Е	209Ж	КТ337А	р-п-р	С-В-Е	337А	КТ364Г	nFET	G-D-S	364Г
КТ209И	р-п-р	С-В-Е	209И	КТ337Б	р-п-р	С-В-Е	337Б	КТ364Д	nFET	G-D-S	364Д
КТ209К	р-п-р	С-В-Е	209К	КТ337В	р-п-р	С-В-Е	337В	КТ364Е	nFET	G-D-S	364Е
КТ209Л	р-п-р	С-В-Е	209Л	КТ339АМ	п-п-п	С-Е-В	339А	КТ364Ж	nFET	G-D-S	364Ж
КТ209М	р-п-р	С-В-Е	209М	КТ342АМ	п-п-п	С-Е-В	342АМ	КТ364И	nFET	G-D-S	364И
КТ219А	п-п-п	С-В-Е	219А	КТ342БМ	п-п-п	С-В-Е	342БМ	КТ368АМ	п-п-п	С-В-Е	368А/М
КТ306АМ	п-п-п	С-В-Е	306АМ	КТ342ВМ	п-п-п	С-В-Е	342ВМ	КТ368БМ	п-п-п	С-В-Е	368Б/М
КТ306БМ	п-п-п	С-В-Е	306Б	КТ342ГМ	п-п-п	С-В-Е	342ГМ	КТ368ВМ	п-п-п	С-В-Е	368ВМ
КТ306ВМ	п-п-п	С-В-Е	306В	КТ342ДМ	п-п-п	С-В-Е	342ДМ	КТ373А	п-п-п	Е-В-С	373А
КТ306ГМ	п-п-п	С-В-Е	306Г	КТ345А	р-п-р	С-В-Е	345А	КТ373Б	п-п-п	Е-В-С	373Б
КТ306ДМ	п-п-п	С-В-Е	306Д	КТ345Б	р-п-р	С-В-Е	345Б	КТ373В	п-п-п	Е-В-С	373В
КТ307А1	п-FET	G-D-S	307А	КТ345В	р-п-р	С-В-Е	345В	КТ373Г	п-п-п	Е-В-С	373Г
КТ307Б1	п-FET	G-D-S	307Б	КТ349А	р-п-р	С-В-Е	349А	КТ375А	п-п-п	С-В-Е	375А
КТ307Г1	п-FET	G-D-S	307Г	КТ349Б	р-п-р	С-В-Е	349Б	КТ375Б	п-п-п	С-В-Е	375Б

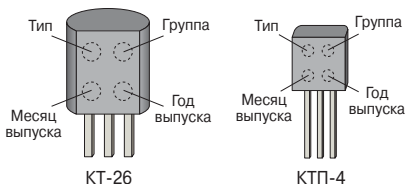
Маркировка отечественных п/п приборов в корпусе КТ-26 (ТО-92)

Тип	Функция		Маркировка	Тип	Функция		Маркировка	Тип	Функция		Маркировка
КТ399АМ	п-р-п	С-В-Е	399А	КТ686Г	р-п-р	С-В-Е	686Г	КТ6110Д	п-р-п	Е-В-С	6110Д
КТ399БМ	п-р-п	С-В-Е	399Б	КТ686Д	р-п-р	С-В-Е	686Д	КТ6111А	п-р-п	Е-В-С	6111А
КТ399ВМ	п-р-п	С-В-Е	399В	КТ686Е	р-п-р	С-В-Е	686Е	КТ6111Б	п-р-п	Е-В-С	6111Б
КТ399ГМ	п-р-п	С-В-Е	399Г	КТ686Ж	р-п-р	С-В-Е	686Ж	КТ6111В	п-р-п	Е-В-С	6111В
КП501А	п-МОС	Г-Д-С	501А	КТ698А	п-р-п	С-В-Е	698А	КТ6111Г	п-р-п	Е-В-С	6111Г
КП501Б	п-МОС	Г-Д-С	501Б	КТ698Б	п-р-п	С-В-Е	698Б	КТ6112А	п-р-п	Е-В-С	6112А
КП501В	п-МОС	Г-Д-С	501В	КТ698В	п-р-п	С-В-Е	698В	КТ6112Б	п-р-п	Е-В-С	6112Б
КП502А	п-МОС	С-Д-Г	502А	КТ698Г	п-р-п	С-В-Е	698Г	КТ6112В	п-р-п	Е-В-С	6112В
КТ502А	р-п-р	С-В-Е	502А	КТ698Д	п-р-п	С-В-Е	698Д	КТ6113А	п-р-п	Е-В-С	6113А
КТ502Б	р-п-р	С-В-Е	502Б	КТ698Е	п-р-п	С-В-Е	698Е	КТ6113Б	п-р-п	Е-В-С	6113Б
КТ502В	р-п-р	С-В-Е	502В	КТ698Ж	п-р-п	С-В-Е	698Ж	КТ6113В	п-р-п	Е-В-С	6113В
КТ502Г	р-п-р	С-В-Е	502Г	КТ698И	п-р-п	С-В-Е	698И	КТ6113Г	п-р-п	Е-В-С	6113Г
КТ502Д	р-п-р	С-В-Е	502Д	КТ698К	п-р-п	С-В-Е	698К	КТ6113Д	п-р-п	Е-В-С	6113Д
КТ502Е	р-п-р	С-В-Е	502Е	КТ3102АМ	п-р-п	С-В-Е	3102АМ	КТ6113Е	п-р-п	Е-В-С	6113Е
КП503А	п-МОС	С-Д-Г	503А	КТ3102БМ	п-р-п	С-В-Е	3102БМ	КТ6114А	п-р-п	Е-В-С	6114А
КП503А	п-р-п	С-В-Е	503А	КТ3102ВМ	п-р-п	С-В-Е	3102ВМ	КТ6114А	п-р-п	Е-В-С	6114А
КТ503Б	п-р-п	С-В-Е	503Б	КТ3102ГМ	п-р-п	С-В-Е	3102ГМ	КТ6114Б	п-р-п	Е-В-С	6114Б
КТ503В	п-р-п	С-В-Е	503В	КТ3102ДМ	п-р-п	С-В-Е	3102ДМ	КТ6114В	п-р-п	Е-В-С	6114В
КТ503Г	п-р-п	С-В-Е	503Г	КТ3102ЕМ	п-р-п	С-В-Е	3102ЕМ	КТ6114Д	п-р-п	Е-В-С	6114Д
КТ503Д	п-р-п	С-В-Е	503Д	КТ3102ЖМ	п-р-п	С-В-Е	3102ЖМ	КТ6114Е	п-р-п	Е-В-С	6114Е
КТ503Е	п-р-п	С-В-Е	503Е	КТ3102ИМ	п-р-п	С-В-Е	3102ИМ	КТ6115А	п-р-п	Е-В-С	6115А
КП504А	п-МОС	С-Д-Г	504А	КТ3102КМ	п-р-п	С-В-Е	3102КМ	КТ6115Б	п-р-п	Е-В-С	6115Б
КП504Б	п-МОС	С-Д-Г	504Б	КТ3107А	п-р-п	В-С-Е	3107А	КТ6115В	п-р-п	Е-В-С	6115В
КП504В	п-МОС	С-Д-Г	504В	КТ3107А1	п-р-п	В-С-Е	3107А1	КТ6115Г	п-р-п	Е-В-С	6115Г
КП505А	п-МОС	С-Д-Г	505А	КТ3107Б	п-р-п	В-С-Е	3107Б	КТ6115Д	п-р-п	Е-В-С	6115Д
КП505Б	п-МОС	С-Д-Г	505Б	КТ3107Б1	п-р-п	В-С-Е	3107Б1	КТ6115Е	п-р-п	Е-В-С	6115Е
КП505В	п-МОС	С-Д-Г	505В	КТ3107В	п-р-п	В-С-Е	3107В	КТ6116А	п-р-п	Е-В-С	6116А
КП505Г	п-МОС	С-Д-Г	505Г	КТ3107В1	п-р-п	В-С-Е	3107В1	КТ6116Б	п-р-п	Е-В-С	6116Б
КП523А	п-МОС	С-Д-Г	505Г	КТ3107Г	п-р-п	В-С-Е	3107Г	КТ6117А	п-р-п	Е-В-С	6117А
КС515Г1	dz		515Г1	КТ3107Г1	п-р-п	В-С-Е	3107Г1	КТ6117Б	п-р-п	Е-В-С	6117Б
КС520В1	dz		520В1	КТ3107Д	п-р-п	В-С-Е	3107Д	КТ6127А	п-р-п	С-В-Е	6127А
КС531В1	dz		531В1	КТ3107Д1	п-р-п	В-С-Е	3107Д1	КТ6127Б	п-р-п	С-В-Е	6127Б
КТ632А1	р-п-р	С-В-Е	632А1	КТ3107Е	п-р-п	В-С-Е	3107Е	КТ6127В	п-р-п	С-В-Е	6127В
КТ632Б1	р-п-р	С-В-Е	632Б1	КТ3107Е1	п-р-п	В-С-Е	3107Е1	КТ6127Г	п-р-п	С-В-Е	6127Г
КТ632В1	р-п-р	С-В-Е	632В1	КТ3107Ж	п-р-п	В-С-Е	3107Ж	КТ6127Д	п-р-п	С-В-Е	6127Д
КТ638А	п-р-п	С-В-Е	638А	КТ3107Ж1	п-р-п	В-С-Е	3107Ж1	КТ6127Е	п-р-п	С-В-Е	6127Е
КТ638Б	п-р-п	С-В-Е	638Б	КТ3107И	п-р-п	В-С-Е	3107И	КТ6127Ж	п-р-п	С-В-Е	6127Ж
КТ645А	п-р-п	С-В-Е	645А	КТ3107И1	п-р-п	В-С-Е	3107И1	КТ6127И	п-р-п	С-В-Е	6127И
КТ645Б	п-р-п	С-В-Е	645Б	КТ3107К	п-р-п	В-С-Е	3107К	КТ6127К	п-р-п	С-В-Е	6127К
КТ660А	п-р-п	С-В-Е	660А	КТ3107К1	п-р-п	В-С-Е	3107К1	КТ6128А	п-р-п	Е-В-С	6128А
КТ660Б	п-р-п	С-В-Е	660Б	КТ3107Л	п-р-п	В-С-Е	3107Л	КТ6128Б	п-р-п	Е-В-С	6128Б
КТ668А	п-р-п	С-В-Е	668А	КТ3107Л1	п-р-п	В-С-Е	3107Л1	КТ6128В	п-р-п	Е-В-С	6128В
КТ668Б	р-п-р	С-В-Е	668Б	КТ3117А1	п-р-п	С-В-Е	3117	КТ6128Г	п-р-п	Е-В-С	6128Г
КТ668В	р-п-р	С-В-Е	668В	КТ3126А	п-р-п	С-В-Е	3126А	КТ6128Д	п-р-п	Е-В-С	6128Д
КТ680А	п-р-п	С-В-Е	680А	КТ3126Б	п-р-п	С-В-Е	3126Б	КТ6128Е	п-р-п	Е-В-С	6128Е
КТ681А	п-р-п	С-В-Е	681А	КТ3128А1	п-р-п	С-В-Е	3128А1	КТ6133А	п-р-п	С-В-Е	6133А
КТ684А	р-п-р	В-С-Е	684А	КТ3128Б1	п-р-п	С-В-Е	3128Б1	КТ6133Б	п-р-п	С-В-Е	6133Б
КТ684Б	р-п-р	В-С-Е	684Б	КТ3166А	п-р-п	С-В-Е	3166А	КТ6133В	п-р-п	С-В-Е	6133В
КТ684В	п-р-п	В-С-Е	684В	КТ3166Б	п-р-п	С-В-Е	3166Б	КТ6134А	п-р-п	С-В-Е	6134А
КТ684Г	р-п-р	В-С-Е	684Г	КТ3166В	п-р-п	С-В-Е	3166В	КТ6134Б	п-р-п	С-В-Е	6134Б
КТ685А	п-р-п	С-В-Е	685А	КТ3166Г	п-р-п	С-В-Е	3166Г	КТ6134В	п-р-п	С-В-Е	6134В
КТ685Б	р-п-р	С-В-Е	685Б	КТ6109А	п-р-п	Е-В-С	6109А	КТ6135А	п-р-п	С-В-Е	6135А
КТ685В	р-п-р	С-В-Е	685В	КТ6109Б	п-р-п	Е-В-С	6109Б	КТ6135Б	п-р-п	С-В-Е	6135Б
КТ685Г	р-п-р	С-В-Е	685Г	КТ6109В	п-р-п	Е-В-С	6109В	КТ6135В	п-р-п	С-В-Е	6135В
КТ685Д	п-р-п	С-В-Е	685Д	КТ6109Г	п-р-п	Е-В-С	6109Г	КТ6135Г	п-р-п	С-В-Е	6135Г
КТ685Е	р-п-р	С-В-Е	685Е	КТ6109Д	п-р-п	Е-В-С	6109Д	КТ6136А	п-р-п	С-В-Е	6136А
КТ685Ж	р-п-р	С-В-Е	685Ж	КТ6110А	п-р-п	Е-В-С	6110А	КТ6137А	п-р-п	С-В-Е	6137А
КТ686А	п-р-п	С-В-Е	686А	КТ6110Б	п-р-п	Е-В-С	6110Б	КР1210ЕН1	ref	К-К-А	ЕН1
КТ686Б	р-п-р	С-В-Е	686Б	КТ6110В	п-р-п	Е-В-С	6110В				
КТ686В	р-п-р	С-В-Е	686В	КТ6110Г	п-р-п	Е-В-С	6110Г				

Маркировка отечественных п/п приборов в корпусе КТ-26 (ТО-92)

Цветовая четырехточечная маркировка

Использовалась до 1986 года. Почти все приборы, отмаркированные четырьмя цветными точками на срезе боковой поверхности корпуса, выпускались как в корпусе КТ-26 (Рис. 18), так и в корпусе КТП-4 (Рис. 19). Точки наносятся цветной эмалью типа ЭП140. Кодирование группы, месяца и года выпуска производится строго согласно цветовым рядам, приведенным в таблицах ниже. Также в последней таблице приведены все варианты данного класса маркировки (расшифровку колонки «Функция» см. в списке сокращений).



М Левая нижняя точка (месяц выпуска)

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Цвет	беж	син	зел	кра	сал	сер	кор	ора	эле	бел	жел	гол

Г Правая нижняя точка (год выпуска)

Год	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Цвет	беж	сал	ора	эле	бир	бел	кра	кор	зел	гол

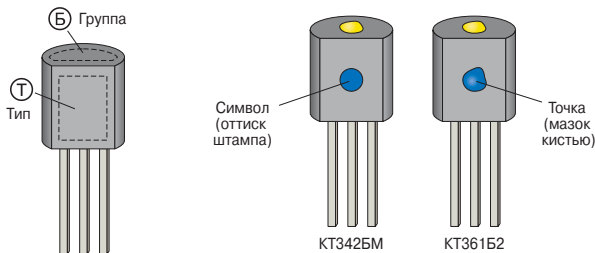
Т Б Варианты маркировки

Т	Тип	Функция		Б Цвет правой верхней точки (буква группы)											
				А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И	К	Л	М	
Цвет левой верхней точки (тип)	гол	КТ3107	р-п-р	С-В-Е	А	Б	В	Г	Д		Е	Ж	И	К	Л
	кор	КТ326	р-п-р	С-В-Е	АМ	БМ									
	кра	КТ337	р-п-р	С-В-Е	А	Б	В								
	бел	КТ345	р-п-р	С-В-Е	А	Б	В								
	син	КТ349	р-п-р	С-В-Е	А	Б	В								
	сер	КТ350	р-п-р	С-В-Е	А										
	жел	КТ351	р-п-р	С-В-Е	А	Б									
	зел	КТ352	р-п-р	С-В-Е	А	Б									
	роз	КТ363	р-п-р	С-В-Е	АМ	БМ									

С В Е
КТ337В
март, 1979

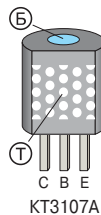
Символьно-цветовая маркировка

Основным признаком является наличие цветных геометрических символов на срезе боковой поверхности корпуса и отсутствие каких-либо букв/цифр. Тип прибора указывается на срезе боковой поверхности корпуса цветным геометрическим символом, группа — на торце корпуса цветными точками (см. рисунок). Различают два способа нанесения маркировки: в первом случае маркировка наносится с помощью накатки и занимает все поверхность от левого края до правого (первая таблица), а во втором случае символ наносится штампом (вторая таблица). Используемые в таблицах условные обозначения расшифрованы в списке сокращений. Следует различать символьную и двухточечную маркировку: кружок-символ наносится с помощью специального штампа и поэтому имеет четкую форму и «оттиснутый» вид, а точка наносится кистью и поэтому не имеет четкой формы, но заполняется краской гораздо более плотно (см. рисунок).




























Символьно-цветовая маркировка накаткой

Т	Тип	Функция		Б Цвет точки на торце (буква группы)														
				нет	крас	бел	зел	гол	2 бел	2 зел	2 кра	2 гол	бел+зел	бел+кра	бел+гол			
Накатка на боковом срезе (тип)		KT3102	п-р-п	С-В-Е	АМ	БМ	ЕМ	ДМ	ВМ		ГМ		ИМ	ЖМ	КМ			
		KT3107	р-п-р	С-В-Е	Ж	К	Б	А	Л	Е	И	В	Г	Д				
		KT316	п-р-п	С-В-Е	АМ	БМ	ВМ	ГМ	ДМ									
		KT3144	п-р-п	С-В-Е	А													
		KT201	п-р-п	С-В-Е	АМ	БМ	ВМ	ГМ	ДМ									
		KT399	п-р-п	С-В-Е	АМ	БМ	ВМ	ГМ										
		KP1064KT1	btд	Д-Г-С	А	Б	В	Г										
		КЖ101	сld	I-C-O	A1													
		KC106	dz	С-В-Е	A1													

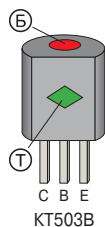


Маркировка отечественных п/п приборов в корпусе КТ-26 (ТО-92)

Символьно-цветовая маркировка геометрической фигурой

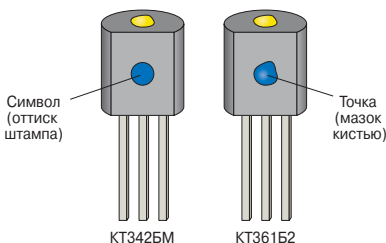
Т	Тип	Функция		Б Цвет точки на торце (буква группы)														
				нет	бел	зел	кра	жел	син	2 бел	2 зел	2 кра	2 жел	2 син				
	КТ645	п-р-п	С-В-Е	А	Б													
	КТ645	п-р-п	С-В-Е		И	Д	В	Г	Е	М	Л	К	Ж					
	КТ645	п-р-п	С-В-Е	А	Б													
	КТ3126	р-п-р	С-В-Е	А		Б												
	КТ361	п-р-р	Е-С-В	А3...*	А2	И2	Г3	Б2	Д2									
	КТ6109	р-п-р	Е-В-С		А	Б	В	Г	Д									
	КТ6110	п-р-п	Е-В-С		А	Б	В	Г	Д									
	КТ6114	п-р-п	Е-В-С		А	Б	В			Г	Д	Е						
	КТ6115	р-п-р	Е-В-С		А	Б	В			Г	Д	Е						
	КТ6116	р-п-р	Е-В-С	А		Б												
	КТ6117	п-р-п	Е-В-С	А	Б													
	КТ502	р-п-р	С-В-Е		А	Б	В	Г	Д	Е								
	КТ503	п-р-п	С-В-Е		А	Б	В	Г	Д	Е								
	КТ315	п-р-п	Е-С-В		Е1	В1	А1	Б1	Г1	Р1	Н1	Ж1	Д1	И1				
	КП365	п-FET	Г-S-D	А	Б													
	КП501	п-MOS	Г-D-S	А	Б	В												
	КТ6111	п-р-п	Е-В-С			В	А	Б	Г									
	КТ3117	р-п-р	С-В-Е	А1														
	КД130	d	А1-К-А2	АС														
	КД130	d	К1-А-К2	АС1														
	КВ134	var	К1-А-К2	А1														
	КВС111	var	А1-К-А2		А	В		Г	Б	Д-2								
	КТ660	п-р-п	С-В-Е	А														
	КТ660	п-р-п	С-В-Е	Б														

*А3, В2, Д3, Е2, Ж2, К2, Л2, М2, Н2, Г2, П2



Цветовая двухточечная маркировка

Отличается наличием цветной точки на срезе боковой поверхности корпуса (капля краски, наносимая кистью вручную), кодирующей тип прибора; на торце корпуса цветной точкой указывается группа. Точки наносятся цветной эмалью типа ЭП140 по ГОСТ 24709-81. Кодирование группы производится согласно цветовому ряду, приведенному во второй строке таблицы с вариантами данного класса маркировки, хотя возможны как частичные нарушения этого ряда, так и полное пренебрежение ими. Расшифровку колонки «Функция» см. в списке сокращений.



Следует различать символическую и двухточечную маркировку: кружок-символ наносится с помощью специального штампа и поэтому имеет четкую форму и «оттиснутый» вид, а точка наносится кистью и поэтому не имеет четкой формы, но заполняется краской гораздо более плотно (см. рисунок).

Т	Тип	Функция	1-2-3	Б Цвет точки на торце (буква группы)												
				нет	роз	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И	К	Л	М
сер	КТ209	р-п-р	С-В-Е			А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И	К	Л	М
т-зел	КТ3102	п-р-п	С-В-Е			АМ	БМ	ВМ	ГМ	ДМ	ЕМ	ЖМ			ИМ	КМ
таб	КП364	п-FET	G-D-S			А	Б	В	Г	Д	Е				И	
кор	КТ326	р-п-р	С-В-Е		АМ		БМ									
т-кра	КТ203	р-п-р	С-В-Е			АМ	БМ	ВМ								
кра	КТ6112	р-п-р	Е-В-С			А	Б	В								
ора	КТ313	р-п-р	С-В-Е			А1	Б1	В1	Г1							
	КТ638	п-р-п	С-В-Е			А	Б	В	Г							
жел	КТ502	р-п-р	С-В-Е			А	Б	В	Г	Д	Е					
гол	КТ6111	п-р-п	Е-В-С			А	Б	В	Г							
	КТ339	п-р-п	С-Е-В	А		А	Б	В		Г						
син	КТ342	п-р-п	С-В-Е			АМ	БМ	ВМ	ГМ	ДМ						
	КВ131	var	А-К	А/А2												
бел	КТ503	п-р-п	С-В-Е			А	Б	В	Г	Д	Е					
срб	КТ632	р-п-р	С-В-Е			А1	Б1	В1								

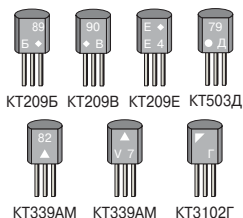
Маркировка отечественных п/п приборов в корпусе КТ-26 (ГО-92)

Символьно-буквенная маркировка

Основным признаком этой маркировки является сочетание геометрических символов, букв и цифр. Срез боковой поверхности корпуса делится на четыре информационных поля. До 1991 года встречались различные порядки использования информационных полей (см. рисунок).

В настоящее время используется следующий порядок: верхнее левое поле обозначает тип прибора (один геометрический символ, буква или цифра), верхнее правое поле — группу (одна буква), нижнее левое поле — год выпуска, нижнее правое — месяц выпуска (дата согласно ГОСТ 25486-82).

Варианты маркировки приведены в таблице.



М Левый нижний символ (год выпуска)

Символ	U	V	W	X	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M
Год	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000

Г Правый нижний символ (месяц выпуска)

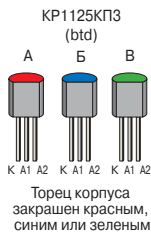
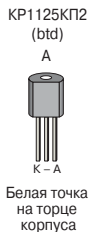
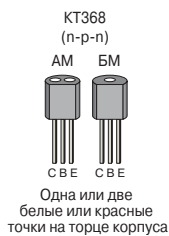
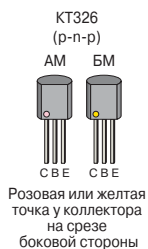
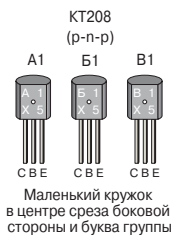
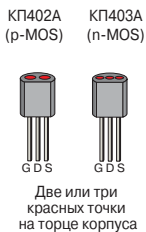
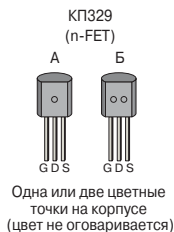
Символ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D
Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

Т Маркировка типонимнала

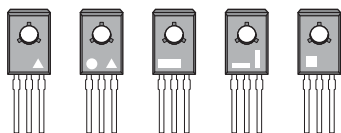
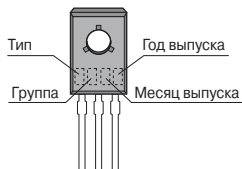
Т	Тип	Функция		Т	Тип	Функция		Т	Тип	Функция		Т	Тип	Функция	
1	КТ632х1	р-п-р	С-В-Е	Ц	КТ6127х	р-п-р	С-В-Е	<p>КТ3102АМ май, 1994</p>							
2	КТ638 КТ3102хМ	п-р-п п-р-п	С-В-Е	С	КТ523х	р-п-р	С-В-Е								
3	КТ3102хМ2	п-р-п	Е-С-В	Т	КТ3166х	п-р-п	Д-Г-С								
4	КТ3102хМ2	п-р-п	Е-С-В	Л	КТ313х1	р-п-п	І-С-О								
7	КТ3107х2	р-п-р	В-С-Е	●	КТ503х	п-р-п	С-В-Е								
І	КТ681А	р-п-р	С-В-Е	◐	КТ502х	р-п-р	С-В-Е								
ІА	КР1157ЕНхх02А	рег+	О-С-І	◑	КТ3102хМ	п-р-п	С-В-Е								
А	КР1157ЕНхх01А КР364х	рег+ п-FET	С-І-О В-С-Е	◒	КТ203хМ	р-п-р	С-В-Е								
Б	КР361х	п-FET	Г-Д-С	◓	КТ3157А	р-п-п	С-Е-В								
В	КР307х1 КР1171СПхх	п-FET vd	Г-Д-С І-С-О	◔	КТ342хМ	п-р-п	С-В-Е								
Г	КР1170ЕНхх КТ680А	рег+ п-р-п	О-С-І О-С-І	◆	КТ209х1	р-п-р	С-В-Е								
Г	КТ680А3	п-р-п	С-В-Е	▼	КТ3107х2 КТ326хМ	р-п-р р-п-р	С-В-Е С-В-Е								
П	КТ517х КТ698х	п-р-п п-р-п	С-В-Е С-В-Е	▲	КТ339хМ	п-р-п	С-Е-В								
									<p>КТ6127Б октябрь, 1992</p>						

Нестандартизируемая маркировка

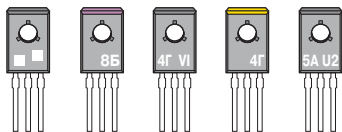
Включает приборы, маркировка которых не подпадает под вышеперечисленные классы. Многие из них приведены ниже.



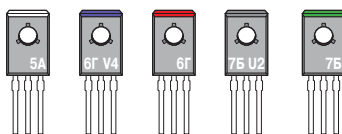
МАРКИРОВКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ П/П ПРИБОРОВ В КОРПУСЕ КТ-27 (ТО-126)



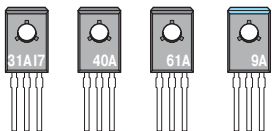
КТ646А КТ646Б КТ972А КТ972Б КТ973А



КТ973Б КТ683Б КТ814Г КТ814Г КТ815А



КТ815А КТ816Г КТ816Г КТ817Б КТ817Б



КТ8131А КТ940 КТ961А КТ9115

МАРКИРОВКА П/П КОМПОНЕТОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

Назначение колонок в таблицах

- Код** — код, нанесенный на корпус. Сортировка по кодам задана с приоритетом цифр перед буквами, следовательно, код 618 расположен раньше, чем код 64S и 6A, а код A1 — после 9A. Бывают ситуации, когда совпадают код и тип корпуса, а приборы разные. Например, на корпусе типа SOT-323 нанесен код 6H. У фирмы «Philips» это *n-p-n*-транзистор типа BC818W, а у фирмы «Motorola» это *p-n-p*-транзистор типа MUN5131T1 с совершенно другими параметрами;
- Типоминал** — типоминал (полное название прибора);
- Б** — сокращенное название фирмы-производителя. Например, SIEM — фирма «Siemens», HP — «Hewlett-Packard» и т.д. Для расшифровки необходимо воспользоваться таблицей «Список фирм-производителей», помещенной в конце книги;
- Ф** — функциональное назначение прибора. Например, *n-p-n*-транзистор с указанной проводимостью, shd — диод Шоттки и т.д. Для расшифровки необходимо воспользоваться таблицей «Список обозначений функции прибора», помещенной в конце книги;
- Особенности** — особенности или основные электрические характеристики прибора. Для расшифровки необходимо воспользоваться таблицей «Список сокращений и условных обозначений», помещенной в конце книги;
- Корпус** — название корпуса (EIAJ, JEDEC...);
- Ц/Цоколевка** — цоколевка. Аббревиатуры выводов приводятся в порядке возрастания номеров выводов, начиная с первого. Нумерация выводов указана на корпусах в колоннотитуле. Для расшифровки необходимо воспользоваться таблицей «Список сокращений и условных обозначений», помещенной в конце книги.



1 2 SOD66, SOD91

SOD66/91

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1 2
11D	BYD11D	PHIL	byg	$V_R < 200 \text{ B}; I_F < 0.5 \text{ A}; V_F(0.5 \text{ A}) < 0.91 \text{ B}; V_R > 225 \text{ B}; I_R < 1 \text{ мкА}; C_D = 14 \text{ нФ}; t_{\text{RR}} = 3 \text{ мкс}$	SOD-91	К * А
11G	BYD11G	PHIL	byg	$V_R < 400 \text{ B}; I_F < 0.5 \text{ A}; V_F(0.5 \text{ A}) < 0.91 \text{ B}; V_R > 450 \text{ B}; I_R < 1 \text{ мкА}; C_D = 14 \text{ нФ}; t_{\text{RR}} = 3 \text{ мкс}$	SOD-91	К * А
11J	BYD11J	PHIL	byg	$V_R < 600 \text{ B}; I_F < 0.5 \text{ A}; V_F(0.5 \text{ A}) < 0.91 \text{ B}; V_R > 650 \text{ B}; I_R < 1 \text{ мкА}; C_D = 14 \text{ нФ}; t_{\text{RR}} = 3 \text{ мкс}$	SOD-91	К * А
11K	BYD11K	PHIL	byg	$V_R < 800 \text{ B}; I_F < 0.5 \text{ A}; V_F(0.5 \text{ A}) < 0.91 \text{ B}; V_R > 900 \text{ B}; I_R < 1 \text{ мкА}; C_D = 14 \text{ нФ}; t_{\text{RR}} = 3 \text{ мкс}$	SOD-91	К * А
11M	BYD11M	PHIL	byg	$V_R < 1000 \text{ B}; I_F < 0.5 \text{ A}; V_F(0.5 \text{ A}) < 0.91 \text{ B}; V_R > 1100 \text{ B}; I_R < 1 \text{ мкА}; C_D = 14 \text{ нФ}; t_{\text{RR}} = 3 \text{ мкс}$	SOD-91	К * А
31D	BYD31D	PHIL	byg	$V_R < 200 \text{ B}; I_F < 0.44 \text{ A}; V_F(0.5 \text{ A}) < 1.35 \text{ B}; V_R > 300 \text{ B}; C_D = 9 \text{ нФ}; t_{\text{RR}} < 250 \text{ нс}$	SOD-91	К * А
31G	BYD31G	PHIL	byg	$V_R < 400 \text{ B}; I_F < 0.44 \text{ A}; V_F(0.5 \text{ A}) < 1.35 \text{ B}; V_R > 500 \text{ B}; C_D = 9 \text{ нФ}; t_{\text{RR}} < 250 \text{ нс}$	SOD-91	К * А
31J	BYD31J	PHIL	byg	$V_R < 600 \text{ B}; I_F < 0.44 \text{ A}; V_F(0.5 \text{ A}) < 1.35 \text{ B}; V_R > 700 \text{ B}; C_D = 9 \text{ нФ}; t_{\text{RR}} < 250 \text{ нс}$	SOD-91	К * А
31K	BYD31K	PHIL	byg	$V_R < 800 \text{ B}; I_F < 0.44 \text{ A}; V_F(0.5 \text{ A}) < 1.35 \text{ B}; V_R > 900 \text{ B}; C_D = 8 \text{ нФ}; t_{\text{RR}} < 300 \text{ нс}$	SOD-91	К * А
31M	BYD31M	PHIL	fid	$V_R < 1000 \text{ B}; I_F < 0.44 \text{ A}; V_F(0.5 \text{ A}) < 1.35 \text{ B}; V_R > 1100 \text{ B}; C_D = 8 \text{ нФ}; t_{\text{RR}} < 300 \text{ нс}$	SOD-91	К * А
C10PH	BZV85-C10	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 25 \text{ mA}) = 9.4...10.6 \text{ B}; Z_{T1} < 8 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C11PH	BZV85-C11	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 20 \text{ mA}) = 10.4...11.6 \text{ B}; Z_{T1} < 10 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C12PH	BZV85-C12	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 20 \text{ mA}) = 11.4...12.7 \text{ B}; Z_{T1} < 10 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C13PH	BZV85-C13	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 20 \text{ mA}) = 12.4...14.1 \text{ B}; Z_{T1} < 10 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C15PH	BZV85-C15	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 15 \text{ mA}) = 13.8...15.6 \text{ B}; Z_{T1} < 15 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C16PH	BZV85-C16	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 15 \text{ mA}) = 15.3...17.1 \text{ B}; Z_{T1} < 15 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C18PH	BZV85-C18	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 15 \text{ mA}) = 16.8...19.1 \text{ B}; Z_{T1} < 20 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C20PH	BZV85-C20	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 10 \text{ mA}) = 18.8...21.2 \text{ B}; Z_{T1} < 24 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C22PH	BZV85-C22	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 10 \text{ mA}) = 20.8...23.3 \text{ B}; Z_{T1} < 25 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C24PH	BZV85-C24	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 10 \text{ mA}) = 22.8...25.6 \text{ B}; Z_{T1} < 30 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C27PH	BZV85-C27	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 8 \text{ mA}) = 25.1...28.9 \text{ B}; Z_{T1} < 40 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C30PH	BZV85-C30	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 8 \text{ mA}) = 28...32 \text{ B}; Z_{T1} < 45 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C33PH	BZV85-C33	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 8 \text{ mA}) = 31...35 \text{ B}; Z_{T1} < 45 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C36PH	BZV85-C36	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 8 \text{ mA}) = 34...38 \text{ B}; Z_{T1} < 50 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C39PH	BZV85-C39	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 6 \text{ mA}) = 37...41 \text{ B}; Z_{T1} < 60 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C3V6PH	BZV85-C3V6	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 60 \text{ mA}) = 3.4...3.8 \text{ B}; Z_{T1} < 15 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C3V9PH	BZV85-C3V9	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 60 \text{ mA}) = 3.7...4.1 \text{ B}; Z_{T1} < 15 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C43PH	BZV85-C43	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 6 \text{ mA}) = 40...46 \text{ B}; Z_{T1} < 75 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C47PH	BZV85-C47	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 4 \text{ mA}) = 44...50 \text{ B}; Z_{T1} < 100 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C4V3PH	BZV85-C4V3	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 50 \text{ mA}) = 4.0...4.6 \text{ B}; Z_{T1} < 13 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C4V7PH	BZV85-C4V7	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 45 \text{ mA}) = 4.4...5.0 \text{ B}; Z_{T1} < 13 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C51PH	BZV85-C51	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 4 \text{ mA}) = 48...54 \text{ B}; Z_{T1} < 125 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C56PH	BZV85-C56	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 4 \text{ mA}) = 52...60 \text{ B}; Z_{T1} < 150 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C5V1PH	BZV85-C5V1	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 45 \text{ mA}) = 4.8...5.4 \text{ B}; Z_{T1} < 10 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C5V6PH	BZV85-C5V6	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 45 \text{ mA}) = 5.2...6.0 \text{ B}; Z_{T1} < 7 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C62PH	BZV85-C62	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 4 \text{ mA}) = 58...66 \text{ B}; Z_{T1} < 175 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C68PH	BZV85-C68	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 4 \text{ mA}) = 64...72 \text{ B}; Z_{T1} < 200 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C6V2PH	BZV85-C6V2	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 35 \text{ mA}) = 5.8...6.6 \text{ B}; Z_{T1} < 4 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C6V8PH	BZV85-C6V8	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 35 \text{ mA}) = 6.4...7.2 \text{ B}; Z_{T1} < 3.5 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C75PH	BZV85-C75	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 4 \text{ mA}) = 70...80 \text{ B}; Z_{T1} < 225 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C7V5PH	BZV85-C7V5	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 35 \text{ mA}) = 7.0...7.9 \text{ B}; Z_{T1} < 3 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C8V2PH	BZV85-C8V2	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 25 \text{ mA}) = 7.7...8.7 \text{ B}; Z_{T1} < 5 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
C9V1PH	BZV85-C9V1	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT} = 25 \text{ mA}) = 8.5...9.6 \text{ B}; Z_{T1} < 5 \text{ Ом}$	SOD-66	К * А
S11	BAS11	PHIL	dl	$V_R < 300 \text{ B}; I_F < 300 \text{ mA}; V_F(I_F = 300 \text{ mA}) < 1.0 \text{ B}; C_D = 20 \text{ нФ}; t_{\text{RR}} < 1 \text{ мкс}$	SOD-91	К * А
S12	BAS12	PHIL	dl	$V_R < 400 \text{ B}; I_F < 300 \text{ mA}; V_F(I_F = 300 \text{ mA}) < 1.0 \text{ B}; C_D = 20 \text{ нФ}; t_{\text{RR}} < 1 \text{ мкс}$	SOD-91	К * А



SOD110, DO214, SMA/B/C

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1+2
01C100PH	BZG01-C100	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 2.7 \text{ mA}) = 94...106 \text{ B}$; $Z_{2T} < 350 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C101PH	BZG01-C10	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 25 \text{ mA}) = 9.4...10.6 \text{ B}$; $Z_{2T} < 7 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C110PH	BZG01-C110	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 2.7 \text{ mA}) = 104...116 \text{ B}$; $Z_{2T} < 450 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C11PH	BZG01-C11	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 20 \text{ mA}) = 10.4...11.6 \text{ B}$; $Z_{2T} < 8 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C120PH	BZG01-C120	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 2 \text{ mA}) = 114...127 \text{ B}$; $Z_{2T} < 550 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C12PH	BZG01-C12	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 20 \text{ mA}) = 11.4...12.7 \text{ B}$; $Z_{2T} < 9 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C130PH	BZG01-C130	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 2 \text{ mA}) = 124...141 \text{ B}$; $Z_{2T} < 700 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C13PH	BZG01-C13	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 20 \text{ mA}) = 12.4...14.1 \text{ B}$; $Z_{2T} < 10 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C150PH	BZG01-C150	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 2 \text{ mA}) = 138...156 \text{ B}$; $Z_{2T} < 1000 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C15PH	BZG01-C15	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 15 \text{ mA}) = 13.8...15.6 \text{ B}$; $Z_{2T} < 15 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C160PH	BZG01-C160	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 1.5 \text{ mA}) = 153...171 \text{ B}$; $Z_{2T} < 1100 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C16PH	BZG01-C16	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 15 \text{ mA}) = 15.3...17.1 \text{ B}$; $Z_{2T} < 15 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C180PH	BZG01-C180	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 1.5 \text{ mA}) = 168...191 \text{ B}$; $Z_{2T} < 1200 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C18PH	BZG01-C18	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 15 \text{ mA}) = 16.8...19.1 \text{ B}$; $Z_{2T} < 20 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C200PH	BZG01-C200	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 1.5 \text{ mA}) = 188...212 \text{ B}$; $Z_{2T} < 1500 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C20PH	BZG01-C20	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 10 \text{ mA}) = 18.8...21.2 \text{ B}$; $Z_{2T} < 24 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C220PH	BZG01-C220	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 1 \text{ mA}) = 208...233 \text{ B}$; $Z_{2T} < 2250 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C22PH	BZG01-C22	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 10 \text{ mA}) = 20.8...23.3 \text{ B}$; $Z_{2T} < 25 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C240PH	BZG01-C240	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 1 \text{ mA}) = 228...256 \text{ B}$; $Z_{2T} < 2550 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C24PH	BZG01-C24	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 10 \text{ mA}) = 22.8...25.6 \text{ B}$; $Z_{2T} < 25 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C270PH	BZG01-C270	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 1 \text{ mA}) = 251...289 \text{ B}$; $Z_{2T} < 3000 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C27PH	BZG01-C27	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 8 \text{ mA}) = 25.1...28.9 \text{ B}$; $Z_{2T} < 30 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C30PH	BZG01-C30	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 8 \text{ mA}) = 28...32 \text{ B}$; $Z_{2T} < 30 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C33PH	BZG01-C33	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 8 \text{ mA}) = 31...35 \text{ B}$; $Z_{2T} < 35 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C36PH	BZG01-C36	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 8 \text{ mA}) = 34...38 \text{ B}$; $Z_{2T} < 40 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C39PH	BZG01-C39	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 6 \text{ mA}) = 37...41 \text{ B}$; $Z_{2T} < 50 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C43PH	BZG01-C43	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 6 \text{ mA}) = 40...46 \text{ B}$; $Z_{2T} < 50 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C47PH	BZG01-C47	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 4 \text{ mA}) = 44...50 \text{ B}$; $Z_{2T} < 90 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C51PH	BZG01-C51	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 4 \text{ mA}) = 48...54 \text{ B}$; $Z_{2T} < 115 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C56PH	BZG01-C56	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 4 \text{ mA}) = 52...60 \text{ B}$; $Z_{2T} < 120 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C62PH	BZG01-C62	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 4 \text{ mA}) = 58...66 \text{ B}$; $Z_{2T} < 125 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C68PH	BZG01-C68	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 4 \text{ mA}) = 64...72 \text{ B}$; $Z_{2T} < 130 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C75PH	BZG01-C75	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 4 \text{ mA}) = 70...79 \text{ B}$; $Z_{2T} < 135 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C82PH	BZG01-C82	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 2.7 \text{ mA}) = 77...87 \text{ B}$; $Z_{2T} < 200 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
01C91PH	BZG01-C91	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 2.7 \text{ mA}) = 85...96 \text{ B}$; $Z_{2T} < 250 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
03C100PH	BZG03-C100	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 5 \text{ mA}) = 94...106 \text{ B}$; $Z_{2T} < 200 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
03C10PH	BZG03-C10	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 50 \text{ mA}) = 9.4...10.6 \text{ B}$; $Z_{2T} < 4 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
03C110PH	BZG03-C110	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 5 \text{ mA}) = 104...116 \text{ B}$; $Z_{2T} < 450 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
03C11PH	BZG03-C11	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 50 \text{ mA}) = 10.4...11.6 \text{ B}$; $Z_{2T} < 7 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
03C120PH	BZG03-C120	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 5 \text{ mA}) = 114...127 \text{ B}$; $Z_{2T} < 250 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
03C12PH	BZG03-C12	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 50 \text{ mA}) = 11.4...12.7 \text{ B}$; $Z_{2T} < 7 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
03C130PH	BZG03-C130	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 5 \text{ mA}) = 124...141 \text{ B}$; $Z_{2T} < 300 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
03C13PH	BZG03-C13	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 50 \text{ mA}) = 12.4...14.1 \text{ B}$; $Z_{2T} < 10 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
03C150PH	BZG03-C150	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 5 \text{ mA}) = 138...156 \text{ B}$; $Z_{2T} < 300 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
03C15PH	BZG03-C15	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 50 \text{ mA}) = 13.8...15.6 \text{ B}$; $Z_{2T} < 10 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
03C160PH	BZG03-C160	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 5 \text{ mA}) = 153...171 \text{ B}$; $Z_{2T} < 350 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
03C16PH	BZG03-C16	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 25 \text{ mA}) = 15.3...17.1 \text{ B}$; $Z_{2T} < 15 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
03C180PH	BZG03-C180	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 5 \text{ mA}) = 168...191 \text{ B}$; $Z_{2T} < 400 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А
03C18PH	BZG03-C18	PHIL	dz	$V_{2(I_{2T})} = 25 \text{ mA}) = 16.8...19.1 \text{ B}$; $Z_{2T} < 15 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К•А



DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типонаимал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
03C200PH	BZG03-C200	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=5\text{ mA})=188...212\text{ B}$; $Z_{T1} < 500\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C20PH	BZG03-C20	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=25\text{ mA})=18.8...21.2\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C220PH	BZG03-C220	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=2\text{ mA})=208...233\text{ B}$; $Z_{T1} < 750\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C22PH	BZG03-C22	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=25\text{ mA})=20.8...23.3\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C240PH	BZG03-C240	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=2\text{ mA})=228...256\text{ B}$; $Z_{T1} < 850\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C24PH	BZG03-C24	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=25\text{ mA})=22.8...25.6\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C270PH	BZG03-C270	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=2\text{ mA})=251...289\text{ B}$; $Z_{T1} < 1000\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C27PH	BZG03-C27	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=25\text{ mA})=25.1...28.9\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C30PH	BZG03-C30	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=25\text{ mA})=28...32\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C33PH	BZG03-C33	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=25\text{ mA})=31...35\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C36PH	BZG03-C36	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=10\text{ mA})=34...38\text{ B}$; $Z_{T1} < 40\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C39PH	BZG03-C39	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=10\text{ mA})=37...41\text{ B}$; $Z_{T1} < 40\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C43PH	BZG03-C43	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=10\text{ mA})=40...46\text{ B}$; $Z_{T1} < 45\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C47PH	BZG03-C47	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=10\text{ mA})=44...50\text{ B}$; $Z_{T1} < 45\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C51PH	BZG03-C51	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=10\text{ mA})=48...54\text{ B}$; $Z_{T1} < 60\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C56PH	BZG03-C56	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=10\text{ mA})=52...60\text{ B}$; $Z_{T1} < 60\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C62PH	BZG03-C62	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=10\text{ mA})=58...66\text{ B}$; $Z_{T1} < 80\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C68PH	BZG03-C68	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=10\text{ mA})=64...72\text{ B}$; $Z_{T1} < 80\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C75PH	BZG03-C75	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=10\text{ mA})=70...79\text{ B}$; $Z_{T1} < 100\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C82PH	BZG03-C82	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=10\text{ mA})=77...87\text{ B}$; $Z_{T1} < 100\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
03C91PH	BZG03-C91	PHIL	dz	$V_{\frac{1}{2}}(I_{ZT}=5\text{ mA})=85...96\text{ B}$; $Z_{T1} < 200\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
04100PH	BZG04-100	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5\text{ mA})=114\text{ B}$; $V_{VM}=167\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0410PH	BZG04-10	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=50\text{ mA})=11.4\text{ B}$; $V_{VM}=17\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
04110PH	BZG04-110	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5\text{ mA})=124\text{ B}$; $V_{VM}=185\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0411PH	BZG04-11	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=50\text{ mA})=12.4\text{ B}$; $V_{VM}=18.9\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
04120PH	BZG04-120	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5\text{ mA})=138\text{ B}$; $V_{VM}=204\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0412PH	BZG04-12	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=50\text{ mA})=13.8\text{ B}$; $V_{VM}=20.9\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
04130PH	BZG04-130	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5\text{ mA})=153\text{ B}$; $V_{VM}=224\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0413PH	BZG04-13	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25\text{ mA})=15.3\text{ B}$; $V_{VM}=22.9\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
04150PH	BZG04-150	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5\text{ mA})=168\text{ B}$; $V_{VM}=249\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0415PH	BZG04-15	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25\text{ mA})=16.8\text{ B}$; $V_{VM}=25.6\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
04160PH	BZG04-160	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5\text{ mA})=188\text{ B}$; $V_{VM}=279\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0416PH	BZG04-16	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25\text{ mA})=18.8\text{ B}$; $V_{VM}=28.4\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
04180PH	BZG04-180	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=2\text{ mA})=208\text{ B}$; $V_{VM}=305\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0418PH	BZG04-18	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25\text{ mA})=20.8\text{ B}$; $V_{VM}=31.0\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
04200PH	BZG04-200	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=2\text{ mA})=228\text{ B}$; $V_{VM}=336\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0420PH	BZG04-20	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25\text{ mA})=22.8\text{ B}$; $V_{VM}=33.8\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
04220PH	BZG04-220	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=2\text{ mA})=251\text{ B}$; $V_{VM}=380\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0422PH	BZG04-22	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25\text{ mA})=25.1\text{ B}$; $V_{VM}=38.1\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0424PH	BZG04-24	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25\text{ mA})=28\text{ B}$; $V_{VM}=42.2\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0427PH	BZG04-27	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=25\text{ mA})=31\text{ B}$; $V_{VM}=46.2\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0430PH	BZG04-30	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10\text{ mA})=34\text{ B}$; $V_{VM}=50.1\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0433PH	BZG04-33	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10\text{ mA})=37\text{ B}$; $V_{VM}=54.1\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0436PH	BZG04-36	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10\text{ mA})=40\text{ B}$; $V_{VM}=60.7\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0439PH	BZG04-39	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10\text{ mA})=44\text{ B}$; $V_{VM}=65.5\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0443PH	BZG04-43	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10\text{ mA})=48\text{ B}$; $V_{VM}=70.8\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0447PH	BZG04-47	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10\text{ mA})=52\text{ B}$; $V_{VM}=78.6\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0451PH	BZG04-51	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10\text{ mA})=58\text{ B}$; $V_{VM}=86.5\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0456PH	BZG04-56	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10\text{ mA})=64\text{ B}$; $V_{VM}=94.4\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0462PH	BZG04-62	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10\text{ mA})=70\text{ B}$; $V_{VM}=103.5\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0468PH	BZG04-68	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=10\text{ mA})=77\text{ B}$; $V_{VM}=114\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0475PH	BZG04-75	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5\text{ mA})=85\text{ B}$; $V_{VM}=126\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0482PH	BZG04-82	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T=5\text{ mA})=94\text{ B}$; $V_{VM}=139\text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	К:1-2
048V2PH	BZG04-8V2	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T = 50 \text{ mA}) = 9.4 \text{ B}$; $V_{VM} = 14.8 \text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
0491PH	BZG04-91	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T = 5 \text{ mA}) = 10.4 \text{ B}$; $V_{VM} = 15.2 \text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
049V1PH	BZG04-9V1	PHIL	vs	$V_{BR}(I_T = 50 \text{ mA}) = 10.4 \text{ B}$; $V_{VM} = 15.7 \text{ B}$	DO-214AC, SMA	К*А
10	SML4740	GS	dz	$V_2 (I_2 = 25.0 \text{ mA}) = 10 \text{ B}$; $Z_{T1} = 7.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
10	U1ZB10	TOSH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 10 \text{ mA}) = 9.0...11.0 \text{ B}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 10 \text{ mA}) < 30 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
100	U1ZB100	TOSH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 3 \text{ mA}) = 90...110 \text{ B}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 3 \text{ mA}) < 300 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
100A	P6SMB10AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 95...105 \text{ B}$; $V_{VM} = 137 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
10A	1.5SMC10AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 9.5...10.5 \text{ B}$; $V_{VM} = 8.55 \text{ B}$; $I_{pp} = 103 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
10A	P6SMB10AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 9.5...10.5 \text{ B}$; $V_{VM} = 14.5 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
11	SML4741	GS	dz	$V_{ZT} (I_Z = 23.0 \text{ mA}) = 11 \text{ B}$; $Z_{T1} = 8.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
11	U1ZB11	TOSH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 10 \text{ mA}) = 9.9...12.1 \text{ B}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 10 \text{ mA}) < 30 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
110	U1ZB110	TOSH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 3 \text{ mA}) = 99...121 \text{ B}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 3 \text{ mA}) < 300 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
110A	P6SMB11AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 105...116 \text{ B}$; $V_{VM} = 15.2 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
11A	1.5SMC11AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 10.5...11.6 \text{ B}$; $V_{VM} = 9.4 \text{ B}$; $I_{pp} = 96 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
11A	P6SMB11AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 10.5...11.6 \text{ B}$; $V_{VM} = 15.6 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
11C	P6SMB11CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 10.5...11.6 \text{ B}$; $V_{VM} = 15.6 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
12	SML4742	GS	dz	$V_2 (I_2 = 21.0 \text{ mA}) = 12 \text{ B}$; $Z_{T1} = 9.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
12	U1ZB12	TOSH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 10 \text{ mA}) = 10.8...13.2 \text{ B}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 10 \text{ mA}) < 30 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
120A	P6SMB12CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 114...126 \text{ B}$; $V_{VM} = 165 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
12A	1.5SMC12AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 11.4...12.6 \text{ B}$; $V_{VM} = 10.2 \text{ B}$; $I_{pp} = 90 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
12A	P6SMB12AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 11.4...12.6 \text{ B}$; $V_{VM} = 16.7 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
12C	P6SMB12CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 11.4...12.6 \text{ B}$; $V_{VM} = 16.7 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
13	SML4743	GS	dz	$V_2 (I_2 = 19.0 \text{ mA}) = 13 \text{ B}$; $Z_{T1} = 10.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
13	U1ZB13	TOSH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 10 \text{ mA}) = 11.7...14.3 \text{ B}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 10 \text{ mA}) < 30 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
130A	P6SMB13CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 124...137 \text{ B}$; $V_{VM} = 179 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
13A	1.5SMC13AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 12.4...13.7 \text{ B}$; $V_{VM} = 11.1 \text{ B}$; $I_{pp} = 82 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
13A	P6SMB13AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 12.4...13.7 \text{ B}$; $V_{VM} = 18.2 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
13C	P6SMB13CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 12.4...13.7 \text{ B}$; $V_{VM} = 18.2 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
15	SML4744	GS	dz	$V_2 (I_2 = 17.0 \text{ mA}) = 15 \text{ B}$; $Z_{T1} = 14.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
15	U1ZB15	TOSH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 10 \text{ mA}) = 13.5...16.5 \text{ B}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 10 \text{ mA}) < 30 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
150	U1ZB150	TOSH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 2 \text{ mA}) = 135...165 \text{ B}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 2 \text{ mA}) < 450 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
150A	P6SMB150AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 143...158 \text{ B}$; $V_{VM} = 207 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
15A	1.5SMC15AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.3...15.8 \text{ B}$; $V_{VM} = 12.8 \text{ B}$; $I_{pp} = 71 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
15A	P6SMB15AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 14.3...15.8 \text{ B}$; $V_{VM} = 21.2 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
15C	P6SMB15CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 14.3...15.8 \text{ B}$; $V_{VM} = 21.2 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
16	SML4745	GS	dz	$V_2 (I_2 = 15.5 \text{ mA}) = 16 \text{ B}$; $Z_{T1} = 16.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
16	U1ZB16	TOSH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 10 \text{ mA}) = 14.4...17.6 \text{ B}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 10 \text{ mA}) < 30 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
160A	P6SMB160AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 152...168 \text{ B}$; $V_{VM} = 219 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
16A	1.5SMC16AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 15.2...16.8 \text{ B}$; $V_{VM} = 13.6 \text{ B}$; $I_{pp} = 67 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
16A	P6SMB16AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 15.2...16.8 \text{ B}$; $V_{VM} = 22.5 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
16C	P6SMB16CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 15.2...16.8 \text{ B}$; $V_{VM} = 22.5 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
170A	P6SMB170AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 162...179 \text{ B}$; $V_{VM} = 234 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
18	SML4746	GS	dz	$V_2 (I_2 = 14.0 \text{ mA}) = 18 \text{ B}$; $Z_{T1} = 20.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
18	U1ZB18	TOSH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 10 \text{ mA}) = 16.2...19.8 \text{ B}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 10 \text{ mA}) < 30 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
180	U1ZB180	TOSH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 1.5 \text{ mA}) = 162...198 \text{ B}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 1.5 \text{ mA}) < 500 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
180A	P6SMB180AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 171...189 \text{ B}$; $V_{VM} = 246 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
18A	1.5SMC18AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.1...18.9 \text{ B}$; $V_{VM} = 15.3 \text{ B}$; $I_{pp} = 59.5 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
18A	P6SMB18AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 17.1...18.9 \text{ B}$; $V_{VM} = 25.2 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
18C	P6SMB18CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 17.1...18.9 \text{ B}$; $V_{VM} = 25.2 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
1C	10BQ015	IR	shd	$V_R < 15 \text{ B}$; $VF < 0.32 \text{ B}$; $I_T < 1 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
1F	10BQ040	IR	shd	$V_R < 40 \text{ B}$; $VF < 0.49 \text{ B}$; $I_T < 1 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
1F	10MQ040N	IR	shd	$V_R < 40 \text{ B}$; $VF < 0.51 \text{ B}$; $I_T < 1.1 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
1J	10BQ100	IR	shd	$V_R < 100 \text{ B}$; $VF < 0.62 \text{ B}$; $I_T < 1 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А



DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
1J	10M100N	IR	shd	$V_R < 100 В$; $V_F < 0.68 В$; $I_F < 2.1 А$	DO-214AC, SMA	К*А
1P	10BF10	IR	shd	$V_R < 100 В$; $V_F < 0.95 В$; $I_F < 1 А$; $I_{RMS} < 100 мкА$; $t_{RR} = 35 нс$	DO-214AA, SMB	К*А
1P	10BF40	IR	shd	$V_R < 400 В$; $V_F < 1.4 В$; $I_F < 1 А$; $I_{RMS} < 100 мкА$; $t_{RR} = 50 нс$	DO-214AA, SMB	К*А
1S	10BF20	IR	shd	$V_R < 200 В$; $V_F < 0.95 В$; $I_F < 1 А$; $I_{RMS} < 100 мкА$; $t_{RR} = 35 нс$	DO-214AA, SMB	К*А
1U	10BF60	IR	shd	$V_R < 600 В$; $V_F < 1.7 В$; $I_F < 1 А$; $I_{RMS} < 100 мкА$; $t_{RR} = 100 нс$	DO-214AA, SMB	К*А
1V	10BF80	IR	shd	$V_R < 800 В$; $V_F < 1.7 В$; $I_F < 1 А$; $I_{RMS} < 100 мкА$; $t_{RR} = 100 нс$	DO-214AA, SMB	К*А
1X	10BF100	IR	shd	$V_R < 1000 В$; $V_F < 1.7 В$; $I_F < 1 А$; $I_{RMS} < 100 мкА$; $t_{RR} = 100 нс$	DO-214AA, SMB	К*А
20	SML4747	GS	dz	$V_Z (Z = 12.5 мА) = 20 В$; $Z_{T1} = 22.0 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
20	U1ZB20	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 18.0...22.0 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
200	U1ZB200	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 180...220 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
200A	P6SMB200AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1 мА) = 190...210 В$; $V_{VM} = 274 В$	DO-214AA, SMB	К*А
200Y	U1ZB200-Y	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 190...210 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
200Z	U1ZB200-Z	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 200...220 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
20A	1.5SMC20AT3	MOT	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 19...21 В$; $V_{VM} = 17.1 В$; $I_{PP} = 54 А$	DO-214AB, SMC	К*А
20A	P6SMB20AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1 мА) = 19...21 В$; $V_{VM} = 27.7 В$	DO-214AA, SMB	К*А
20C	P6SMB20CAT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1 мА) = 19...21 В$; $V_{VM} = 27.7 В$	DO-214AA, SMB	К*Х
22	SML4748	GS	dz	$V_Z (I_Z = 11.5 мА) = 22 В$; $Z_{T1} = 23.0 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
22	U1ZB22	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 19.8...24.2 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
220	U1ZB220	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 198...242 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
220Y	U1ZB220-Y	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 210...230 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
220Z	U1ZB220-Z	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 220...240 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
22A	1.5SMC22AT3	MOT	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 20.9...23.1 В$; $V_{VM} = 18.8 В$; $I_{PP} = 49 А$	DO-214AB, SMC	К*А
22A	P6SMB22AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1 мА) = 20.9...23.1 В$; $V_{VM} = 30.6 В$	DO-214AA, SMB	К*А
22C	P6SMB22CAT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1 мА) = 20.9...23.1 В$; $V_{VM} = 30.6 В$	DO-214AA, SMB	К*Х
24	SML4749	GS	dz	$V_Z (I_Z = 10.5 мА) = 24 В$; $Z_{T1} = 25.0 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
24	U1ZB24	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 21.6...26.4 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
240	U1ZB240	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 216...264 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
240Y	U1ZB240-Y	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 230...250 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
240Z	U1ZB240-Z	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 240...260 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
24A	1.5SMC24AT3	MOT	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 22.8...25.2 В$; $V_{VM} = 20.5 В$; $I_{PP} = 45 А$	DO-214AB, SMC	К*А
24A	P6SMB24AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1 мА) = 22.8...25.2 В$; $V_{VM} = 33.2 В$	DO-214AA, SMB	К*А
24C	P6SMB24CAT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1 мА) = 22.8...25.2 В$; $V_{VM} = 33.2 В$	DO-214AA, SMB	К*Х
27	SML4750	GS	dz	$V_Z (I_Z = 9.5 мА) = 27 В$; $Z_{T1} = 35.0 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
27	U1ZB27	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 24.3...29.7 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
270	U1ZB270	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 243...297 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
270X	U1ZB270-X	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 250...270 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
270Y	U1ZB270-Y	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 260...280 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
270Z	U1ZB270-Z	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 270...290 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
27A	1.5SMC27AT3	MOT	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 25.7...28.4 В$; $V_{VM} = 23.1 В$; $I_{PP} = 40 А$	DO-214AB, SMC	К*А
27A	P6SMB27AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1 мА) = 25.7...28.4 В$; $V_{VM} = 37.5 В$	DO-214AA, SMB	К*А
27C	P6SMB27CAT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1 мА) = 25.7...28.4 В$; $V_{VM} = 37.5 В$	DO-214AA, SMB	К*Х
30	SML4751	GS	dz	$V_Z (I_Z = 8.5 мА) = 30 В$; $Z_{T1} = 40.0 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
30	U1ZB30	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 27.0...33.0 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
300	U1ZB300	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 270...330 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
300X	U1ZB300-X	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 280...300 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
300Y	U1ZB300-Y	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 290...310 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
300Z	U1ZB300-Z	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 300...320 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
30A	1.5SMC30AT3	MOT	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 мА) = 28.5...31.5 В$; $V_{VM} = 25.6 В$; $I_{PP} = 36 А$	DO-214AB, SMC	К*А
30A	P6SMB30AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1 мА) = 28.5...31.5 В$; $V_{VM} = 41.4 В$	DO-214AA, SMB	К*А
30C	P6SMB30CAT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1 мА) = 28.5...31.5 В$; $V_{VM} = 41.4 В$	DO-214AA, SMB	К*Х
33	SML4752	GS	dz	$V_Z (I_Z = 7.5 мА) = 33 В$; $Z_{T1} = 45.0 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
33	U1ZB33	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 10 мА) = 29.7...36.3 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 10 мА) < 30 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А
330	U1ZB330	TOSH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 0.5 мА) = 297...363 В$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 500 Ом$	DO-214AC, SMA	К*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1-2
330X	U1ZB330-X	TOSH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=0.5\text{ mA})=310\dots330\text{ B}$; $Z_{ZT}(I_{ZT}=0.5\text{ mA}) < 5000\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
330Y	U1ZB330-Y	TOSH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=0.5\text{ mA})=320\dots340\text{ B}$; $Z_{ZT}(I_{ZT}=0.5\text{ mA}) < 5000\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
330Z	U1ZB330-Z	TOSH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=0.5\text{ mA})=330\dots350\text{ B}$; $Z_{ZT}(I_{ZT}=0.5\text{ mA}) < 5000\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
33A	1.5SMC33AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=31.4\dots34.7\text{ B}$; $V_{MM}=28.2\text{ B}$; $I_{pp}=33\text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
33A	P6SMB33AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=31.4\dots34.7\text{ B}$; $V_{MM}=45.7\text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
33C	P6SMB33CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=31.4\dots34.7\text{ B}$; $V_{MM}=45.7\text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
36	SML4753	GS	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=7.0\text{ mA})=36\text{ B}$; $Z_{ZT}=50.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
36	U1ZB36	TOSH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=9\text{ mA})=32.4\dots39.6\text{ B}$; $Z_{ZT}(I_{ZT}=9\text{ mA}) < 30\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
36A	1.5SMC36AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=34.2\dots37.8\text{ B}$; $V_{MM}=30.8\text{ B}$; $I_{pp}=30\text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
36A	P6SMB36AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=34.2\dots37.8\text{ B}$; $V_{MM}=49.9\text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
36C	P6SMB36CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=34.2\dots37.8\text{ B}$; $V_{MM}=49.9\text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
39	SML4754	GS	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=6.5\text{ mA})=39\text{ B}$; $Z_{ZT}=60.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
390	U1ZB390	TOSH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=0.5\text{ mA})=351\dots429\text{ B}$; $Z_{ZT}(I_{ZT}=0.5\text{ mA}) < 10000\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
39A	1.5SMC39AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=37.1\dots41\text{ B}$; $V_{MM}=33.3\text{ B}$; $I_{pp}=28\text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
39A	P6SMB39AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=37.1\dots41.0\text{ B}$; $V_{MM}=53.9\text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
39C	P6SMB39CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=37.1\dots41.0\text{ B}$; $V_{MM}=53.9\text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
3C	30B0015	IR	shd	$V_R=15\text{ B}$; $V_F < 0.3\text{ B}$; $I_F=3\text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
3F	15M040N	IR	shd	$V_R < 40\text{ B}$; $V_F < 0.43\text{ B}$; $I_F < 3\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
3F	30B0040	IR	shd	$V_R=40\text{ B}$; $V_F < 0.43\text{ B}$; $I_F=3\text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
3H	30B0060	IR	shd	$V_R=60\text{ B}$; $V_F < 0.52\text{ B}$; $I_F=3\text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
3J	30B0100	IR	shd	$V_R=100\text{ B}$; $V_F < 0.62\text{ B}$; $I_F=3\text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
43	SML4755	GS	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=6.0\text{ mA})=43\text{ B}$; $Z_{ZT}=70.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
43	U1ZB43	TOSH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=7\text{ mA})=38.7\dots47.3\text{ B}$; $Z_{ZT}(I_{ZT}=7\text{ mA}) < 40\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
43A	1.5SMC43AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=40.9\dots45.2\text{ B}$; $V_{MM}=36.8\text{ B}$; $I_{pp}=25.3\text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
43A	P6SMB43AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=40.9\dots45.2\text{ B}$; $V_{MM}=59.3\text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
43C	P6SMB43CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=40.9\dots45.2\text{ B}$; $V_{MM}=59.3\text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
47	SML4756	GS	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5.5\text{ mA})=47\text{ B}$; $Z_{ZT}=80.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
47	U1ZB47	TOSH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=6\text{ mA})=42.3\dots51.7\text{ B}$; $Z_{ZT}(I_{ZT}=6\text{ mA}) < 65\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
47A	1.5SMC47AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=44.7\dots49.4\text{ B}$; $V_{MM}=40.2\text{ B}$; $I_{pp}=23.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
47A	P6SMB47AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=44.7\dots49.4\text{ B}$; $V_{MM}=64.8\text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
47C	P6SMB47CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=44.7\dots49.4\text{ B}$; $V_{MM}=64.8\text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
51	SML4757	GS	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5.0\text{ mA})=51\text{ B}$; $Z_{ZT}=95.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
51	U1ZB51	TOSH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=6\text{ mA})=45.9\dots56.1\text{ B}$; $Z_{ZT}(I_{ZT}=6\text{ mA}) < 65\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
51A	1.5SMC51AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=48.5\dots53.6\text{ B}$; $V_{MM}=43.6\text{ B}$; $I_{pp}=21.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
51A	P6SMB51AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=48.5\dots53.6\text{ B}$; $V_{MM}=70.1\text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
51C	P6SMB51CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=48.5\dots53.6\text{ B}$; $V_{MM}=70.1\text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
56	SML4758	GS	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=4.5\text{ mA})=56\text{ B}$; $Z_{ZT}=110.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
56A	1.5SMC56AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=53.2\dots58.8\text{ B}$; $V_{MM}=47.8\text{ B}$; $I_{pp}=19.5\text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
56A	P6SMB56AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=53.2\dots58.8\text{ B}$; $V_{MM}=77\text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
56C	P6SMB56CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=53.2\dots58.8\text{ B}$; $V_{MM}=77\text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
6.8	U1ZB6.8	TOSH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=10\text{ mA})=6.2\dots7.4\text{ B}$; $Z_{ZT}(I_{ZT}=10\text{ mA}) < 60\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
62	SML4759	GS	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=4.0\text{ mA})=62\text{ B}$; $Z_{ZT}=125.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
62A	1.5SMC62AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=58.9\dots65.1\text{ B}$; $V_{MM}=53\text{ B}$; $I_{pp}=17.7\text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
62A	P6SMB62AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=58.9\dots65.1\text{ B}$; $V_{MM}=85\text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
62C	P6SMB62CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=58.9\dots65.1\text{ B}$; $V_{MM}=85\text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
68	SML4760	GS	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=3.7\text{ mA})=68\text{ B}$; $Z_{ZT}=150.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
68	U1ZB68	TOSH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=4\text{ mA})=61.2\dots74.8\text{ B}$; $Z_{ZT}(I_{ZT}=4\text{ mA}) < 120\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
68A	1.5SMC68AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=64.6\dots71.4\text{ B}$; $V_{MM}=58.1\text{ B}$; $I_{pp}=16.3\text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
68A	P6SMB68AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=64.6\dots71.4\text{ B}$; $V_{MM}=92\text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
68C	P6SMB68CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1\text{ mA})=64.6\dots71.4\text{ B}$; $V_{MM}=92\text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
6P2	SML4735	GS	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=41.0\text{ mA})=6.2\text{ B}$; $Z_{ZT}=2.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
6P8	SML4736	GS	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=37.0\text{ mA})=6.8\text{ B}$; $Z_{ZT}=3.5\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
6VA	1.5SMC6.8AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.45\dots7.14\text{ B}$; $V_{MM}=5.8\text{ B}$; $I_{pp}=143\text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А

**DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
6V8A	P6SMB.8AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 10 \text{ mA}) = 6.45...7.14 \text{ B}$; $V_{MM} = 10.5 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
7.5	U1ZB7.5	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT} = 10 \text{ mA}) = 6.8...8.3 \text{ B}$; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 10 \text{ mA}) < 30 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
75	SML4761	GS	dz	$V_Z(I_{ZT} = 3.3 \text{ mA}) = 75 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 175.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
75	U1ZB75	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT} = 4 \text{ mA}) = 67.5...82.5 \text{ B}$; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 4 \text{ mA}) < 150 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
75A	1.5SMC75AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 71.3...78.8 \text{ B}$; $V_{MM} = 64.1 \text{ B}$; $I_{pp} = 14.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
75A	P6SMB75AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 71.3...78.8 \text{ B}$; $V_{MM} = 103 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
75C	P6SMB75CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 71.3...78.8 \text{ B}$; $V_{MM} = 103 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*Х
7P5	SML4737	GS	dz	$V_Z(I_Z = 34.0 \text{ mA}) = 7.5 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 4.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
7V5A	1.5SMC7.5AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 7.13...7.88 \text{ B}$; $V_{MM} = 6.4 \text{ B}$; $I_{pp} = 132 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
7V5A	P6SMB7.5AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 10 \text{ mA}) = 7.13...7.88 \text{ B}$; $V_{MM} = 11.3 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
8.2	U1ZB8.2	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT} = 10 \text{ mA}) = 7.4...9.1 \text{ B}$; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 10 \text{ mA}) < 30 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
813B	1SMA5913BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 113.6 \text{ mA}) = 3.3 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 10.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
814B	1SMA5914BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 104.2 \text{ mA}) = 3.6 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 9.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
815B	1SMA5915BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 96.1 \text{ mA}) = 3.9 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 7.5 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
816B	1SMA5916BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 87.2 \text{ mA}) = 4.3 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 6.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
817B	1SMA5917BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 79.8 \text{ mA}) = 4.7 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 5.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
818B	1SMA5918BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 73.5 \text{ mA}) = 5.1 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 4.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
819B	1SMA5919BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 66.9 \text{ mA}) = 5.6 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 2.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
82	SML4762	GS	dz	$V_Z(I_Z = 3.0 \text{ mA}) = 82 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 200.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
82	U1ZB82	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT} = 3 \text{ mA}) = 73.8...90.2 \text{ B}$; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 3 \text{ mA}) < 170 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
820B	1SMA5920BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 60.5 \text{ mA}) = 6.2 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 2.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
821B	1SMA5921BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 55.1 \text{ mA}) = 6.8 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 2.5 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
822B	1SMA5922BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 50.0 \text{ mA}) = 7.5 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 3.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
823B	1SMA5923BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 45.7 \text{ mA}) = 8.2 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 3.5 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
824B	1SMA5924BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 41.2 \text{ mA}) = 9.1 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 4.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
825B	1SMA5925BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 37.5 \text{ mA}) = 10 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 4.5 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
826B	1SMA5926BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 34.1 \text{ mA}) = 11 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 5.5 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
827B	1SMA5927BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 31.2 \text{ mA}) = 12 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 6.5 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
828B	1SMA5928BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 28.8 \text{ mA}) = 13 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 7.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
829B	1SMA5929BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 25.0 \text{ mA}) = 15 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 9.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
82A	1.5SMC82AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 77.9...86.1 \text{ B}$; $V_{MM} = 70.1 \text{ B}$; $I_{pp} = 13.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
82A	P6SMB82AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 77.9...86.1 \text{ B}$; $V_{MM} = 113 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
82C	P6SMB82CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1 \text{ mA}) = 77.9...86.1 \text{ B}$; $V_{MM} = 113 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*Х
830B	1SMA5930BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 23.4 \text{ mA}) = 16 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 10 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
831B	1SMA5931BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 20.8 \text{ mA}) = 18 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 12 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
832B	1SMA5932BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 18.7 \text{ mA}) = 20 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 14 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
833B	1SMA5933BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 17.0 \text{ mA}) = 22 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 17.5 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
834B	1SMA5934BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 15.6 \text{ mA}) = 24 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 19 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
835B	1SMA5935BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 13.9 \text{ mA}) = 27 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 23 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
836B	1SMA5936BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 12.5 \text{ mA}) = 30 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 26 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
837B	1SMA5937BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 11.4 \text{ mA}) = 33 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 33 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
838B	1SMA5938BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 10.4 \text{ mA}) = 36 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 38 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
839B	1SMA5939BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 9.6 \text{ mA}) = 39 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 45 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
840B	1SMA5940BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 8.7 \text{ mA}) = 43 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 53 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
841B	1SMA5941BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 8.0 \text{ mA}) = 47 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 67 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
842B	1SMA5942BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 7.3 \text{ mA}) = 51 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 70 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
843B	1SMA5943BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 6.7 \text{ mA}) = 56 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 86 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
844B	1SMA5944BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 6.0 \text{ mA}) = 62 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 100 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
845B	1SMA5945BT3	ON	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5.5 \text{ mA}) = 68 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 120 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
8P2	SML4738	GS	dz	$V_Z(I_Z = 31.0 \text{ mA}) = 8.2 \text{ B}$; $Z_{ZT} = 4.5 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
8V2A	1.5SMC8.2AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 7.79...8.61 \text{ B}$; $V_{MM} = 7.02 \text{ B}$; $I_{pp} = 124 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
8V2A	P6SMB8.2AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 10 \text{ mA}) = 7.79...8.61 \text{ B}$; $V_{MM} = 12.1 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
9.1	U1ZB9.1	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT} = 10 \text{ mA}) = 8.2...10.1 \text{ B}$; $Z_{ZT}(I_{ZT} = 10 \text{ mA}) < 30 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1-2
91	SML4763	GS	dz	$V_2 (I_2 = 2.0 \text{ mA}) = 91 \text{ B}; Z_{T1} = 250.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
913B	1SMB5913BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 113.6 \text{ mA}) = 3.3 \text{ B}; Z_{T1} = 10.0 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
914B	1SMB5914BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 104.2 \text{ mA}) = 3.6 \text{ B}; Z_{T1} = 9.0 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
915B	1SMB5915BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 96.1 \text{ mA}) = 3.9 \text{ B}; Z_{T1} = 7.5 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
916B	1SMB5916BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 87.2 \text{ mA}) = 4.3 \text{ B}; Z_{T1} = 6.0 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
917B	1SMB5917BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 79.8 \text{ mA}) = 4.7 \text{ B}; Z_{T1} = 5.0 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
918B	1SMB5918BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 73.5 \text{ mA}) = 5.1 \text{ B}; Z_{T1} = 4.0 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
919B	1SMB5919BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 66.9 \text{ mA}) = 5.6 \text{ B}; Z_{T1} = 2.0 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
91A	1.SSMC91AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_1 = 1.0 \text{ mA}) = 86.5...95.5 \text{ B}; V_{VM} = 77.8 \text{ B}; I_{PP} = 12 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
91A	P6SMB91AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_1 = 1 \text{ mA}) = 86.5...95.5 \text{ B}; V_{VM} = 125 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
91C	P6SMB91CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_1 = 1 \text{ mA}) = 86.5...95.5 \text{ B}; V_{VM} = 125 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	x*x
920B	1SMB5920BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 60.5 \text{ mA}) = 6.2 \text{ B}; Z_{T1} = 2.0 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
921B	1SMB5921BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 55.1 \text{ mA}) = 6.8 \text{ B}; Z_{T1} = 2.5 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
922B	1SMB5922BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 50.0 \text{ mA}) = 7.5 \text{ B}; Z_{T1} = 3.0 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
923B	1SMB5923BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 45.7 \text{ mA}) = 8.2 \text{ B}; Z_{T1} = 3.5 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
924B	1SMB5924BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 41.2 \text{ mA}) = 9.1 \text{ B}; Z_{T1} = 4.0 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
925B	1SMB5925BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 37.5 \text{ mA}) = 10 \text{ B}; Z_{T1} = 4.5 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
926B	1SMB5926BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 34.1 \text{ mA}) = 11 \text{ B}; Z_{T1} = 5.5 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
927B	1SMB5927BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 31.2 \text{ mA}) = 12 \text{ B}; Z_{T1} = 6.5 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
928B	1SMB5928BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 28.8 \text{ mA}) = 13 \text{ B}; Z_{T1} = 7.0 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
929B	1SMB5929BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 25.0 \text{ mA}) = 15 \text{ B}; Z_{T1} = 9.0 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
930B	1SMB5930BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 23.4 \text{ mA}) = 16 \text{ B}; Z_{T1} = 10 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
931B	1SMB5931BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 20.8 \text{ mA}) = 18 \text{ B}; Z_{T1} = 12 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
932B	1SMB5932BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 18.7 \text{ mA}) = 20 \text{ B}; Z_{T1} = 14 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
933B	1SMB5933BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 17.0 \text{ mA}) = 22 \text{ B}; Z_{T1} = 17.5 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
934B	1SMB5934BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 15.6 \text{ mA}) = 24 \text{ B}; Z_{T1} = 19 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
935B	1SMB5935BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 13.9 \text{ mA}) = 27 \text{ B}; Z_{T1} = 23 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
936B	1SMB5936BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 12.5 \text{ mA}) = 30 \text{ B}; Z_{T1} = 28 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
937B	1SMB5937BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 11.4 \text{ mA}) = 33 \text{ B}; Z_{T1} = 33 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
938B	1SMB5938BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 10.4 \text{ mA}) = 36 \text{ B}; Z_{T1} = 38 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
939B	1SMB5939BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 9.6 \text{ mA}) = 39 \text{ B}; Z_{T1} = 45 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
940B	1SMB5940BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 8.7 \text{ mA}) = 43 \text{ B}; Z_{T1} = 53 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
941B	1SMB5941BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 8.0 \text{ mA}) = 47 \text{ B}; Z_{T1} = 67 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
942B	1SMB5942BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 7.3 \text{ mA}) = 51 \text{ B}; Z_{T1} = 70 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
943B	1SMB5943BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 6.7 \text{ mA}) = 56 \text{ B}; Z_{T1} = 86 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
944B	1SMB5944BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 6.0 \text{ mA}) = 62 \text{ B}; Z_{T1} = 100 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
945B	1SMB5945BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 5.5 \text{ mA}) = 68 \text{ B}; Z_{T1} = 120 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
946B	1SMB5946BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 5.0 \text{ mA}) = 75 \text{ B}; Z_{T1} = 140 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
947B	1SMB5947BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 4.6 \text{ mA}) = 82 \text{ B}; Z_{T1} = 160 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
948B	1SMB5948BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 4.1 \text{ mA}) = 91 \text{ B}; Z_{T1} = 200 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
949B	1SMB5949BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 3.7 \text{ mA}) = 100 \text{ B}; Z_{T1} = 250 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
950B	1SMB5950BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 3.4 \text{ mA}) = 110 \text{ B}; Z_{T1} = 300 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
951B	1SMB5951BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 3.1 \text{ mA}) = 120 \text{ B}; Z_{T1} = 380 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
952B	1SMB5952BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 2.9 \text{ mA}) = 130 \text{ B}; Z_{T1} = 450 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
953B	1SMB5953BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 2.5 \text{ mA}) = 150 \text{ B}; Z_{T1} = 600 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
954B	1SMB5954BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 2.3 \text{ mA}) = 160 \text{ B}; Z_{T1} = 700 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
955B	1SMB5955BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 2.1 \text{ mA}) = 180 \text{ B}; Z_{T1} = 900 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
956B	1SMB5956BТ3	ON	dz	$V_2 (I_2 = 1.9 \text{ mA}) = 200 \text{ B}; Z_{T1} = 1200 \text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
9P1	SML4739	GS	dz	$V_2 (I_2 = 28.0 \text{ mA}) = 9.1 \text{ B}; Z_{T1} = 5.0 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
9V1A	1.SSMC91AT3	MOT	vs	$V_{BR}(I_1 = 10.0 \text{ mA}) = 8.65...9.55 \text{ B}; V_{VM} = 7.78 \text{ B}; I_{PP} = 112 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
9V1A	P6SMB91AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_1 = 1 \text{ mA}) = 8.65...9.55 \text{ B}; V_{VM} = 13.4 \text{ B}$	DO-214AA, SMB	К*А
A6	BAS216	PHIL	di	$V_R < 75 \text{ B}; I_s < 250 \text{ mA}; V_F (I_F = 150 \text{ mA}) < 1.25 \text{ B}; I_s < 50 \text{ mA}; C_0 < 1.5 \text{ нФ}; t_{RR} < 4 \text{ нс}$	SOD-110	К*А



DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
AD	SMBJ5.0C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.40...7.55\text{ B}; V_{VM}=5.0\text{ B}; I_{PP}=62.5\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
ADP	TPSMA6.8	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.12...7.48\text{ B}; V_{VM}=5.50\text{ B}; I_{PP}=37.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AE	SMBJ5.0CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.40...7.23\text{ B}; V_{VM}=5.0\text{ B}; I_{PP}=65.2\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
AP	TPSMA6.8A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.45...7.14\text{ B}; V_{VM}=5.80\text{ B}; I_{PP}=38.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AF	SMBJ6.0C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.67...8.45\text{ B}; V_{VM}=6.0\text{ B}; I_{PP}=52.6\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
AFP	TPSMA7.5	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.75...8.25\text{ B}; V_{VM}=6.05\text{ B}; I_{PP}=34.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AG	SMBJ6.0CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.67...7.67\text{ B}; V_{VM}=6.0\text{ B}; I_{PP}=58.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
AGP	TPSMA7.5A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.13...7.88\text{ B}; V_{VM}=6.40\text{ B}; I_{PP}=35.4\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AH	SMBJ6.5C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.22...9.14\text{ B}; V_{VM}=6.5\text{ B}; I_{PP}=48.7\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
AHP	TPSMA8.2	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.38...9.02\text{ B}; V_{VM}=6.63\text{ B}; I_{PP}=32.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AK	SMBJ6.5CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.22...8.30\text{ B}; V_{VM}=6.5\text{ B}; I_{PP}=53.6\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
AKP	TPSMA8.2A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.79...8.61\text{ B}; V_{VM}=7.02\text{ B}; I_{PP}=33.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AL	SMBJ7.0C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.78...9.86\text{ B}; V_{VM}=7.0\text{ B}; I_{PP}=45.1\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
ALP	TPSMA9.1	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.19...10.00\text{ B}; V_{VM}=7.37\text{ B}; I_{PP}=29.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AM	SMBJ7.0CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.78...8.95\text{ B}; V_{VM}=7.0\text{ B}; I_{PP}=50.0\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
AMP	TPSMA9.1A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.65...9.55\text{ B}; V_{VM}=7.78\text{ B}; I_{PP}=29.9\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AN	SMBJ7.5C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.33...10.80\text{ B}; V_{VM}=7.5\text{ B}; I_{PP}=42.0\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
ANP	TPSMA10	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.00...11.00\text{ B}; V_{VM}=8.10\text{ B}; I_{PP}=26.7\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AP	SMBJ7.5CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.33...9.58\text{ B}; V_{VM}=7.5\text{ B}; I_{PP}=46.5\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
APP	TPSMA10A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.50...10.50\text{ B}; V_{VM}=8.65\text{ B}; I_{PP}=27.6\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AQ	SMBJ8.0C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.89...11.30\text{ B}; V_{VM}=8.0\text{ B}; I_{PP}=40.0\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
AQP	TPSMA11	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.90...12.10\text{ B}; V_{VM}=8.92\text{ B}; I_{PP}=24.7\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AR	SMBJ8.0CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.89...10.23\text{ B}; V_{VM}=8.0\text{ B}; I_{PP}=44.1\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
ARP	TPSMA11A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=10.50...11.60\text{ B}; V_{VM}=9.40\text{ B}; I_{PP}=25.6\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AS	SMBJ8.5C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.44...11.92\text{ B}; V_{VM}=8.5\text{ B}; I_{PP}=37.7\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
ASP	TPSMA12	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=10.80...13.20\text{ B}; V_{VM}=9.72\text{ B}; I_{PP}=23.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AT	SMBJ8.5CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.44...10.82\text{ B}; V_{VM}=8.5\text{ B}; I_{PP}=41.7\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
ATP	TPSMA12A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.40...12.60\text{ B}; V_{VM}=10.20\text{ B}; I_{PP}=24.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AU	SMBJ9.0C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=10.00...12.80\text{ B}; V_{VM}=9.0\text{ B}; I_{PP}=35.5\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
AUP	TPSMA13	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.70...14.30\text{ B}; V_{VM}=10.50\text{ B}; I_{PP}=21.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AV	pSMBJ9.0CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=10.00...11.50\text{ B}; V_{VM}=9.0\text{ B}; I_{PP}=39.0\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
AVP	TPSMA13A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=12.40...13.70\text{ B}; V_{VM}=11.10\text{ B}; I_{PP}=22.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AW	SMBJ10C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.10...14.10\text{ B}; V_{VM}=10.0\text{ B}; I_{PP}=31.9\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
AWP	TPSMA15	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=13.50...16.30\text{ B}; V_{VM}=12.10\text{ B}; I_{PP}=18.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AX	SMBJ10CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.10...12.80\text{ B}; V_{VM}=10.0\text{ B}; I_{PP}=35.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
AXP	TPSMA15A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=14.30...15.80\text{ B}; V_{VM}=12.80\text{ B}; I_{PP}=18.9\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AY	SMBJ11C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=12.20...15.40\text{ B}; V_{VM}=11.0\text{ B}; I_{PP}=29.9\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
AYP	TPSMA16	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=14.40...17.60\text{ B}; V_{VM}=12.90\text{ B}; I_{PP}=17.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
AZ	SMBJ11CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=12.20...14.40\text{ B}; V_{VM}=11.0\text{ B}; I_{PP}=33.0\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
AZP	TPSMA16A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=15.20...16.80\text{ B}; V_{VM}=13.60\text{ B}; I_{PP}=17.8\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
BD	SMBJ12C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=13.30...16.90\text{ B}; V_{VM}=12.0\text{ B}; I_{PP}=27.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
BDD	SMCJ5.0C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.40...7.55\text{ B}; V_{VM}=5.0\text{ B}; I_{PP}=156.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDE	SMCJ5.0CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.40...7.25\text{ B}; V_{VM}=5.0\text{ B}; I_{PP}=163.0\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDF	SMCJ6.0C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.67...8.45\text{ B}; V_{VM}=6.0\text{ B}; I_{PP}=131.6\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDG	SMCJ6.0CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.67...7.67\text{ B}; V_{VM}=6.0\text{ B}; I_{PP}=145.6\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDH	SMCJ6.5C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.22...9.14\text{ B}; V_{VM}=6.5\text{ B}; I_{PP}=122.0\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDK	SMCJ6.5CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.22...8.30\text{ B}; V_{VM}=6.5\text{ B}; I_{PP}=133.9\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDL	SMCJ7.0C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.78...9.86\text{ B}; V_{VM}=7.0\text{ B}; I_{PP}=112.8\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDM	SMCJ7.0CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.78...8.95\text{ B}; V_{VM}=7.0\text{ B}; I_{PP}=125.0\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDN	SMCJ7.5C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.33...10.80\text{ B}; V_{VM}=7.5\text{ B}; I_{PP}=104.9\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDP	SMCJ7.5CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.33...9.58\text{ B}; V_{VM}=7.5\text{ B}; I_{PP}=116.3\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDP	TPSMA18	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=16.20...19.80\text{ B}; V_{VM}=14.50\text{ B}; I_{PP}=15.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
BDQ	SMCJ8.0C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.89...11.30\text{ B}; V_{VM}=8.0\text{ B}; I_{PP}=100.0\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1-2
BDR	SMCJ8.0CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 8.89 \dots 10.23 \text{ B}$; $V_{MM} = 8.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 110.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDS	SMCJ8.5C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 9.44 \dots 11.92 \text{ B}$; $V_{MM} = 8.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 94.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDT	SMCJ8.5CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 9.44 \dots 10.82 \text{ B}$; $V_{MM} = 8.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 104.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDU	SMCJ9.0C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 10.00 \dots 12.80 \text{ B}$; $V_{MM} = 9.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 88.7 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDV	SMCJ9.0CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 10.00 \dots 11.50 \text{ B}$; $V_{MM} = 9.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 97.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDO	SMCJ10C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 11.10 \dots 14.10 \text{ B}$; $V_{MM} = 10.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 79.8 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDX	SMCJ10CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 11.10 \dots 12.80 \text{ B}$; $V_{MM} = 10.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 88.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDY	SMCJ11C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 12.20 \dots 15.40 \text{ B}$; $V_{MM} = 11.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 74.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BDZ	SMCJ11CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 12.20 \dots 14.40 \text{ B}$; $V_{MM} = 11.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 82.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BE	SMBJ12CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 13.30 \dots 15.30 \text{ B}$; $V_{MM} = 12.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 30.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
BED	SMCJ12C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 13.30 \dots 16.90 \text{ B}$; $V_{MM} = 12.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 68.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEE	SMCJ12CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 13.30 \dots 15.30 \text{ B}$; $V_{MM} = 12.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 75.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEF	SMCJ13C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.40 \dots 18.20 \text{ B}$; $V_{MM} = 13.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 63.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEG	SMCJ13CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.40 \dots 16.50 \text{ B}$; $V_{MM} = 13.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 69.7 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEH	SMCJ14C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 15.60 \dots 19.80 \text{ B}$; $V_{MM} = 14.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 58.1 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEK	SMCJ14CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 15.60 \dots 17.90 \text{ B}$; $V_{MM} = 14.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 64.7 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEL	SMCJ15C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.70 \dots 21.10 \text{ B}$; $V_{MM} = 15.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 55.8 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEM	SMCJ15CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.70 \dots 19.20 \text{ B}$; $V_{MM} = 15.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 61.5 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEN	SMCJ16C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.80 \dots 22.60 \text{ B}$; $V_{MM} = 16.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 52.1 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEP	SMCJ16CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.80 \dots 20.50 \text{ B}$; $V_{MM} = 16.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 57.7 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEQ	TPSMA18A	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.10 \dots 18.90 \text{ B}$; $V_{MM} = 15.30 \text{ B}$; $I_{PP} = 15.9 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
BEQ	SMCJ17C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 18.90 \dots 23.90 \text{ B}$; $V_{MM} = 17.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 49.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BES	SMCJ17CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 18.90 \dots 21.70 \text{ B}$; $V_{MM} = 17.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 53.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEE	SMCJ18C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20.00 \dots 25.30 \text{ B}$; $V_{MM} = 18.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 46.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BET	SMCJ18CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20.00 \dots 23.30 \text{ B}$; $V_{MM} = 18.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 51.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEU	SMCJ20C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.20 \dots 28.10 \text{ B}$; $V_{MM} = 20.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 41.9 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEV	SMCJ20CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.20 \dots 25.50 \text{ B}$; $V_{MM} = 20.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 46.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEW	SMCJ22C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 24.40 \dots 30.90 \text{ B}$; $V_{MM} = 22.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 38.1 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEX	SMCJ22CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 24.40 \dots 28.00 \text{ B}$; $V_{MM} = 22.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 42.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEY	SMCJ24C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 26.70 \dots 33.80 \text{ B}$; $V_{MM} = 24.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 34.9 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BEZ	SMCJ24CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 26.70 \dots 30.70 \text{ B}$; $V_{MM} = 24.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 38.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BF	SMBJ13C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.40 \dots 18.20 \text{ B}$; $V_{MM} = 13.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 25.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
BFD	SMCJ26C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 28.90 \dots 36.80 \text{ B}$; $V_{MM} = 26.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 32.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFE	SMCJ26CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 28.90 \dots 33.20 \text{ B}$; $V_{MM} = 26.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 35.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFF	SMCJ28C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 31.10 \dots 39.40 \text{ B}$; $V_{MM} = 28.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 30.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFG	SMCJ28CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 31.10 \dots 35.80 \text{ B}$; $V_{MM} = 28.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 33.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFH	SMCJ30C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 33.30 \dots 42.40 \text{ B}$; $V_{MM} = 30.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 28.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFK	SMCJ30CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 33.30 \dots 38.30 \text{ B}$; $V_{MM} = 30.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 31.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFL	SMCJ33C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 36.70 \dots 46.90 \text{ B}$; $V_{MM} = 33.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 25.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFM	SMCJ33CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 36.70 \dots 42.20 \text{ B}$; $V_{MM} = 33.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 28.1 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFN	SMCJ36C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 40.00 \dots 50.70 \text{ B}$; $V_{MM} = 36.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 23.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFP	SMCJ36CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 40.00 \dots 46.00 \text{ B}$; $V_{MM} = 36.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 25.8 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFP	TPSMA20	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 18.00 \dots 22.00 \text{ B}$; $V_{MM} = 16.20 \text{ B}$; $I_{PP} = 13.7 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
BFO	SMCJ40C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 44.40 \dots 56.30 \text{ B}$; $V_{MM} = 40.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 21.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFR	SMCJ40CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 44.40 \dots 51.10 \text{ B}$; $V_{MM} = 40.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 23.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFS	SMCJ43C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 47.80 \dots 60.50 \text{ B}$; $V_{MM} = 43.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 19.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFT	SMCJ43CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 47.80 \dots 54.90 \text{ B}$; $V_{MM} = 43.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 21.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFU	SMCJ45C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 50.00 \dots 63.30 \text{ B}$; $V_{MM} = 45.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 18.7 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFV	SMCJ45CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 50.00 \dots 57.50 \text{ B}$; $V_{MM} = 45.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 20.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFW	SMCJ48C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 53.30 \dots 67.50 \text{ B}$; $V_{MM} = 48.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 17.5 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFX	SMCJ48CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 53.30 \dots 61.30 \text{ B}$; $V_{MM} = 48.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 19.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFY	SMCJ51C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 56.70 \dots 71.80 \text{ B}$; $V_{MM} = 51.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 16.5 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x
BFZ	SMCJ51CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 56.70 \dots 65.20 \text{ B}$; $V_{MM} = 51.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 18.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x



1 2

DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
BG	SMBJ13CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=14.40...16.50\text{ B}$; $V_{WM}=13.0\text{ B}$; $I_{pp}=27.9\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x*x
BGD	SMCJ54C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=60.00...76.00\text{ B}$; $V_{WM}=54.0\text{ B}$; $I_{pp}=15.6\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGE	SMCJ54CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=60.00...69.00\text{ B}$; $V_{WM}=54.0\text{ B}$; $I_{pp}=17.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGF	SMCJ58C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=64.40...81.60\text{ B}$; $V_{WM}=58.0\text{ B}$; $I_{pp}=14.6\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGG	SMCJ58CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=64.40...74.60\text{ B}$; $V_{WM}=58.0\text{ B}$; $I_{pp}=16.0\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGH	SMCJ60C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=66.70...84.50\text{ B}$; $V_{WM}=60.0\text{ B}$; $I_{pp}=14.0\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGK	SMCJ60CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=66.70...76.70\text{ B}$; $V_{WM}=60.0\text{ B}$; $I_{pp}=15.5\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGL	SMCJ64C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=71.10...90.10\text{ B}$; $V_{WM}=64.0\text{ B}$; $I_{pp}=13.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGM	SMCJ64CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=71.10...81.80\text{ B}$; $V_{WM}=64.0\text{ B}$; $I_{pp}=14.6\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGN	SMCJ70C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=77.80...98.60\text{ B}$; $V_{WM}=70.0\text{ B}$; $I_{pp}=12.0\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGP	SMCJ70CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=77.80...89.50\text{ B}$; $V_{WM}=70.0\text{ B}$; $I_{pp}=13.3\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGP	TPSMA20A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=19.00...21.00\text{ B}$; $V_{WM}=17.10\text{ B}$; $I_{pp}=14.4\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
BGQ	SMCJ75C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=83.30...106.00\text{ B}$; $V_{WM}=75.0\text{ B}$; $I_{pp}=11.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGR	SMCJ75CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=83.30...95.80\text{ B}$; $V_{WM}=75.0\text{ B}$; $I_{pp}=12.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGS	SMCJ78C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=86.70...110.00\text{ B}$; $V_{WM}=78.0\text{ B}$; $I_{pp}=10.8\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGT	SMCJ78CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=86.70...99.70\text{ B}$; $V_{WM}=78.0\text{ B}$; $I_{pp}=11.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGU	SMCJ85C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=94.40...119.20\text{ B}$; $V_{WM}=85.0\text{ B}$; $I_{pp}=9.9\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGV	SMCJ85CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=94.40...108.20\text{ B}$; $V_{WM}=85.0\text{ B}$; $I_{pp}=10.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGW	SMCJ90C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=100.00...126.50\text{ B}$; $V_{WM}=90.0\text{ B}$; $I_{pp}=9.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGX	SMCJ90CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=100.00...115.50\text{ B}$; $V_{WM}=90.0\text{ B}$; $I_{pp}=10.3\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGY	SMCJ100C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=111.00...141.00\text{ B}$; $V_{WM}=100.0\text{ B}$; $I_{pp}=8.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BGZ	SMCJ100CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=111.00...128.00\text{ B}$; $V_{WM}=100.0\text{ B}$; $I_{pp}=9.3\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BH	SMBJ14C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=15.60...19.80\text{ B}$; $V_{WM}=14.0\text{ B}$; $I_{pp}=23.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x*x
BHD	SMCJ110C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=122.00...154.50\text{ B}$; $V_{WM}=110.0\text{ B}$; $I_{pp}=7.7\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BHE	SMCJ110CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=122.00...140.50\text{ B}$; $V_{WM}=110.0\text{ B}$; $I_{pp}=8.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BHF	SMCJ120C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=133.00...169.00\text{ B}$; $V_{WM}=120.0\text{ B}$; $I_{pp}=7.0\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BHG	SMCJ120CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=133.00...153.00\text{ B}$; $V_{WM}=120.0\text{ B}$; $I_{pp}=7.9\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BHH	SMCJ130C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=144.00...182.50\text{ B}$; $V_{WM}=130.0\text{ B}$; $I_{pp}=6.5\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BHK	SMCJ130CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=144.00...165.50\text{ B}$; $V_{WM}=130.0\text{ B}$; $I_{pp}=7.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BHL	SMCJ150C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=167.00...211.50\text{ B}$; $V_{WM}=150.0\text{ B}$; $I_{pp}=5.6\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BHM	SMCJ150CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=167.00...192.50\text{ B}$; $V_{WM}=150.0\text{ B}$; $I_{pp}=6.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BHN	SMCJ160C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=178.00...226.00\text{ B}$; $V_{WM}=160.0\text{ B}$; $I_{pp}=5.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BHP	SMCJ160CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=178.00...205.00\text{ B}$; $V_{WM}=160.0\text{ B}$; $I_{pp}=5.8\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BHP	TPSMA22	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=19.80...24.20\text{ B}$; $V_{WM}=17.80\text{ B}$; $I_{pp}=12.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
BHQ	SMCJ170C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=189.00...239.50\text{ B}$; $V_{WM}=170.0\text{ B}$; $I_{pp}=4.9\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BHR	SMCJ170CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=189.00...217.50\text{ B}$; $V_{WM}=170.0\text{ B}$; $I_{pp}=5.5\text{ A}$	DO-214AB, SMC	x*x*x
BK	SMBJ14CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=15.60...17.90\text{ B}$; $V_{WM}=14.0\text{ B}$; $I_{pp}=25.8\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x*x
BKP	TPSMA22A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=20.90...23.10\text{ B}$; $V_{WM}=18.80\text{ B}$; $I_{pp}=13.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
BL	SMBJ15C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=16.70...21.10\text{ B}$; $V_{WM}=15.0\text{ B}$; $I_{pp}=22.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x*x
BLP	TPSMA24	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=21.60...26.40\text{ B}$; $V_{WM}=19.40\text{ B}$; $I_{pp}=11.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
BM	SMBJ15CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=16.70...19.20\text{ B}$; $V_{WM}=15.0\text{ B}$; $I_{pp}=24.0\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x*x
BMP	TPSMA24A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=22.80...25.20\text{ B}$; $V_{WM}=20.50\text{ B}$; $I_{pp}=12.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
BN	SMBJ16C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=17.80...22.60\text{ B}$; $V_{WM}=16.0\text{ B}$; $I_{pp}=20.8\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x*x
BNP	TPSMA27	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=24.30...29.70\text{ B}$; $V_{WM}=21.80\text{ B}$; $I_{pp}=10.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
BOP	TPSMA30	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=27.00...33.00\text{ B}$; $V_{WM}=24.30\text{ B}$; $I_{pp}=9.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
BP	SMBJ16CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=17.80...20.50\text{ B}$; $V_{WM}=16.0\text{ B}$; $I_{pp}=23.1\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x*x
BPP	TPSMA27A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=25.70...28.40\text{ B}$; $V_{WM}=23.10\text{ B}$; $I_{pp}=10.7\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
BQ	SMBJ17C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=18.90...23.90\text{ B}$; $V_{WM}=17.0\text{ B}$; $I_{pp}=19.7\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x*x
BR	SMBJ17CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=18.90...21.70\text{ B}$; $V_{WM}=17.0\text{ B}$; $I_{pp}=21.7\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x*x
BRP	TPSMA30A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=28.50...31.50\text{ B}$; $V_{WM}=25.60\text{ B}$; $I_{pp}=9.7\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
BS	SMBJ18C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=20.00...25.30\text{ B}$; $V_{WM}=18.0\text{ B}$; $I_{pp}=18.6\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x*x
BSP	TPSMA33	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=29.70...36.30\text{ B}$; $V_{WM}=26.80\text{ B}$; $I_{pp}=8.4\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
BT	SMBJ18CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=20.00...23.30\text{ B}$; $V_{WM}=18.0\text{ B}$; $I_{pp}=20.5\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x*x



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	К:1-2
BTP	TPSMA33A	GS	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 31.40...34.70 \text{ B}$; $V_{MM} = 28.20 \text{ B}$; $I_{pp} = 8.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
BU	SMBJ20C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 22.20...28.10 \text{ B}$; $V_{MM} = 20.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 16.7 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
BUP	TPSMA36	GS	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 32.40...39.60 \text{ B}$; $V_{MM} = 29.10 \text{ B}$; $I_{pp} = 7.7 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
BV	SMBJ20CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 22.20...25.50 \text{ B}$; $V_{MM} = 20.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 18.5 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
BVP	TPSMA36A	GS	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 34.20...37.80 \text{ B}$; $V_{MM} = 30.80 \text{ B}$; $I_{pp} = 8.0 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
BW	SMBJ22C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 24.40...30.90 \text{ B}$; $V_{MM} = 22.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 15.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
BWP	TPSMA39	GS	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 35.10...42.90 \text{ B}$; $V_{MM} = 31.60 \text{ B}$; $I_{pp} = 7.1 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
BX	SMBJ22CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 24.40...28.00 \text{ B}$; $V_{MM} = 22.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 16.9 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
BXP	TPSMA39A	GS	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 37.10...41.00 \text{ B}$; $V_{MM} = 33.30 \text{ B}$; $I_{pp} = 7.4 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
BY	SMBJ24C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 26.70...33.80 \text{ B}$; $V_{MM} = 24.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 14.0 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
BYP	TPSMA43	GS	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 38.70...47.30 \text{ B}$; $V_{MM} = 34.80 \text{ B}$; $I_{pp} = 6.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
BZ	SMBJ24CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 26.70...30.70 \text{ B}$; $V_{MM} = 24.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 15.4 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
BZP	TPSMA43A	GS	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 40.90...45.20 \text{ B}$; $V_{MM} = 36.80 \text{ B}$; $I_{pp} = 6.7 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
C2	SMBY703-200	STM	frd	$V_R < 200 \text{ B}$; $I_R < 3 \text{ A}$; $V_F(I_F = 3 \text{ A}) < 1.4 \text{ B}$; $I_S < 0.6 \text{ mA}$; $t_{RR} < 60 \text{ HC}$	DO-214AB, SMC	К•А
C3	SMBY703-300	STM	frd	$V_R < 300 \text{ B}$; $I_R < 3 \text{ A}$; $V_F(I_F = 3 \text{ A}) < 1.4 \text{ B}$; $I_S < 0.6 \text{ mA}$; $t_{RR} < 60 \text{ HC}$	DO-214AB, SMC	К•А
C4	SMBY703-400	STM	frd	$V_R < 400 \text{ B}$; $I_R < 3 \text{ A}$; $V_F(I_F = 3 \text{ A}) < 1.4 \text{ B}$; $I_S < 0.6 \text{ mA}$; $t_{RR} < 60 \text{ HC}$	DO-214AB, SMC	К•А
CD	SMBJ26C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 28.90...36.80 \text{ B}$; $V_{MM} = 26.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 12.4 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CE	SMBJ26CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 28.90...33.20 \text{ B}$; $V_{MM} = 26.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 14.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CF	SMBJ28C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 31.10...39.40 \text{ B}$; $V_{MM} = 28.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 12.0 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CG	SMBJ28CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 31.10...35.80 \text{ B}$; $V_{MM} = 28.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 13.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CH	SMB30C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 33.30...42.20 \text{ B}$; $V_{MM} = 30.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 11.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	х•х
CK	SMBJ30CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 33.30...38.30 \text{ B}$; $V_{MM} = 30.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 12.4 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CL	SMBJ33C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 36.70...46.90 \text{ B}$; $V_{MM} = 33.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 10.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CM	SMBJ33CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 36.70...42.20 \text{ B}$; $V_{MM} = 33.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 11.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CN	SMBJ36C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 40.00...50.70 \text{ B}$; $V_{MM} = 36.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 9.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CP	SMBJ36CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 40.00...46.00 \text{ B}$; $V_{MM} = 36.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 10.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CQ	SMBJ40C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 44.40...56.30 \text{ B}$; $V_{MM} = 40.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 8.4 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CR	SMBJ40CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 44.40...51.10 \text{ B}$; $V_{MM} = 40.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 9.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CS	SMBJ43C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 47.80...60.50 \text{ B}$; $V_{MM} = 43.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 7.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CT	SMBJ43CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 47.80...54.90 \text{ B}$; $V_{MM} = 43.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 8.6 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CU	SMBJ45C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 50.00...63.30 \text{ B}$; $V_{MM} = 45.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 7.5 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CW	SMBJ45CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 50.00...57.50 \text{ B}$; $V_{MM} = 45.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 8.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CV	SMBJ48C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 53.30...67.50 \text{ B}$; $V_{MM} = 48.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 7.0 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CX	SMBJ48CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 53.30...61.30 \text{ B}$; $V_{MM} = 48.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 7.7 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CY	SMBJ51C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 56.70...71.80 \text{ B}$; $V_{MM} = 51.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 6.6 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
CZ	SMBJ51CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 56.70...65.20 \text{ B}$; $V_{MM} = 51.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 7.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
D20	SMBYW04-200	STM	frd	$V_R < 200 \text{ B}$; $I_R < 4 \text{ A}$; $V_F(I_F = 4 \text{ A}) < 0.85 \text{ B}$; $I_S < 0.5 \text{ mA}$; $t_{RR} < 35 \text{ HC}$	DO-214AB, SMC	К•А
DD	SMBJ54C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 60.00...76.00 \text{ B}$; $V_{MM} = 54.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 6.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
DDP	TPSMC6.8	GS	vs	$V_{BR}(I_f = 10.0 \text{ mA}) = 6.12...7.48 \text{ B}$; $V_{MM} = 5.50 \text{ B}$; $I_{pp} = 139 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К•А
DE	SMBJ54CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 60.00...69.00 \text{ B}$; $V_{MM} = 54.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 6.9 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
DEF	TPSMC6.8A	GS	vs	$V_{BR}(I_f = 10.0 \text{ mA}) = 6.45...7.14 \text{ B}$; $V_{MM} = 5.80 \text{ B}$; $I_{pp} = 143 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К•А
DF	SMBJ58C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 64.40...81.60 \text{ B}$; $V_{MM} = 58.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 5.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
DFF	TPSMC7.5	GS	vs	$V_{BR}(I_f = 10.0 \text{ mA}) = 6.75...8.25 \text{ B}$; $V_{MM} = 6.05 \text{ B}$; $I_{pp} = 128 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К•А
DG	SMBJ58CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 64.40...74.60 \text{ B}$; $V_{MM} = 58.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 6.4 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
DGP	TPSMC7.5A	GS	vs	$V_{BR}(I_f = 10.0 \text{ mA}) = 7.13...7.88 \text{ B}$; $V_{MM} = 6.40 \text{ B}$; $I_{pp} = 133 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К•А
DH	SMBJ60C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 66.70...84.50 \text{ B}$; $V_{MM} = 60.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 5.6 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
DHP	TPSMC8.2	GS	vs	$V_{BR}(I_f = 10.0 \text{ mA}) = 7.38...9.02 \text{ B}$; $V_{MM} = 6.63 \text{ B}$; $I_{pp} = 120 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К•А
DK	SMBJ60CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 66.70...76.70 \text{ B}$; $V_{MM} = 60.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 6.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
DKP	TPSMC8.2A	GS	vs	$V_{BR}(I_f = 10.0 \text{ mA}) = 7.79...8.61 \text{ B}$; $V_{MM} = 7.02 \text{ B}$; $I_{pp} = 124 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К•А
DL	SMBJ64C	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 71.10...90.10 \text{ B}$; $V_{MM} = 64.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 5.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
DLP	TPSMC9.1	GS	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 8.19...10.0 \text{ B}$; $V_{MM} = 7.37 \text{ B}$; $I_{pp} = 109 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К•А
DM	SMBJ64CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 71.10...81.80 \text{ B}$; $V_{MM} = 64.0 \text{ B}$; $I_{pp} = 5.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х•х
DMP	TPSMC9.1A	GS	vs	$V_{BR}(I_f = 1.0 \text{ mA}) = 8.65...9.55 \text{ B}$; $V_{MM} = 7.78 \text{ B}$; $I_{pp} = 112 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К•А



DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
DN	SMBJ70C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=77.80...98.60\text{ B}; V_{MM}=70.0\text{ B}; I_{pp}=4.8\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
DNP	TPSMC10	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.00...11.0\text{ B}; V_{MM}=8.10\text{ B}; I_{pp}=100\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
DOP	TPSMC11	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.90...12.1\text{ B}; V_{MM}=8.92\text{ B}; I_{pp}=92.6\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
DP	SMBJ70CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=77.80...89.50\text{ B}; V_{MM}=70.0\text{ B}; I_{pp}=5.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
DPP	TPSMC10A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.50...10.5\text{ B}; V_{MM}=8.55\text{ B}; I_{pp}=103\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
DQ	SMBJ75C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=83.30...106.00\text{ B}; V_{MM}=75.0\text{ B}; I_{pp}=4.5\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
DR	SMBJ75CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=83.30...95.80\text{ B}; V_{MM}=75.0\text{ B}; I_{pp}=4.9\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
DRP	TPSMC11A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=10.5...11.6\text{ B}; V_{MM}=9.40\text{ B}; I_{pp}=96.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
DS	SMBJ78C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=86.70...110.00\text{ B}; V_{MM}=78.0\text{ B}; I_{pp}=4.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
DSP	TPSMC12	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=10.8...13.2\text{ B}; V_{MM}=9.72\text{ B}; I_{pp}=86.7\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
DT	SMBJ78CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=86.70...99.70\text{ B}; V_{MM}=78.0\text{ B}; I_{pp}=4.7\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
DTP	TPSMC12A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.4...12.6\text{ B}; V_{MM}=10.2\text{ B}; I_{pp}=89.8\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
DU	SMBJ85C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=94.40...119.20\text{ B}; V_{MM}=85.0\text{ B}; I_{pp}=3.9\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
DUP	TPSMC13	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.7...14.3\text{ B}; V_{MM}=10.5\text{ B}; I_{pp}=78.9\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
DV	SMBJ85CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=94.40...108.20\text{ B}; V_{MM}=85.0\text{ B}; I_{pp}=4.4\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
DVP	TPSMC13A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=12.4...13.7\text{ B}; V_{MM}=11.1\text{ B}; I_{pp}=82.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
DW	SMBJ90C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=100.0...126.50\text{ B}; V_{MM}=90.0\text{ B}; I_{pp}=3.8\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
DWP	TPSMC15	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=13.5...16.5\text{ B}; V_{MM}=12.1\text{ B}; I_{pp}=68.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
DX	SMBJ90CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=100.0...115.50\text{ B}; V_{MM}=90.0\text{ B}; I_{pp}=4.1\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
DXP	TPSMC15A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=14.3...15.8\text{ B}; V_{MM}=12.8\text{ B}; I_{pp}=70.8\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
DY	SMBJ100C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=111.0...141.00\text{ B}; V_{MM}=100.0\text{ B}; I_{pp}=3.4\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
DYP	TPSMC16	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=14.4...17.6\text{ B}; V_{MM}=12.9\text{ B}; I_{pp}=63.8\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
DZ	SMBJ100CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=111.0...128.00\text{ B}; V_{MM}=100.0\text{ B}; I_{pp}=3.7\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
DZP	TPSMC16A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=15.2...16.8\text{ B}; V_{MM}=13.6\text{ B}; I_{pp}=66.7\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
EA	ES1A	GS	fd	$V_R=50\text{ B}; I_T=1\text{ A}; C_0=7\text{ nF}$	DO-214AC, SMA	K*A
EA	ES2A	GS	fd	$V_R=50\text{ B}; I_T=2\text{ A}; C_0=18\text{ nF}$	DO-214AA, SMB	K*A
EA	ES3A	GS	fd	$V_R=50\text{ B}; I_T=3\text{ A}; C_0=45\text{ nF}$	DO-214AB, SMC	K*A
EB	ES1B	GS	fd	$V_R=100\text{ B}; I_T=1\text{ A}; C_0=7\text{ nF}$	DO-214AC, SMA	K*A
EB	ES2B	GS	fd	$V_R=100\text{ B}; I_T=2\text{ A}; C_0=18\text{ nF}$	DO-214AA, SMB	K*A
EB	ES3B	GS	fd	$V_R=100\text{ B}; I_T=3\text{ A}; C_0=45\text{ nF}$	DO-214AB, SMC	K*A
EC	ES1C	GS	fd	$V_R=150\text{ B}; I_T=1\text{ A}; C_0=7\text{ nF}$	DO-214AC, SMA	K*A
EC	ES2C	GS	fd	$V_R=150\text{ B}; I_T=2\text{ A}; C_0=18\text{ nF}$	DO-214AA, SMB	K*A
EC	ES3C	GS	fd	$V_R=150\text{ B}; I_T=3\text{ A}; C_0=45\text{ nF}$	DO-214AB, SMC	K*A
ED	ES1D	GS	fd	$V_R=200\text{ B}; I_T=1\text{ A}; C_0=7\text{ nF}$	DO-214AC, SMA	K*A
ED	ES2D	GS	fd	$V_R=200\text{ B}; I_T=2\text{ A}; C_0=18\text{ nF}$	DO-214AA, SMB	K*A
ED	ES3D	GS	fd	$V_R=200\text{ B}; I_T=3\text{ A}; C_0=45\text{ nF}$	DO-214AB, SMC	K*A
ED	SMBJ110C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=122.0...154.50\text{ B}; V_{MM}=110.0\text{ B}; I_{pp}=3.0\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
EDP	TPSMC18	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=16.2...19.8\text{ B}; V_{MM}=14.5\text{ B}; I_{pp}=56.6\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
EE	SMBJ110CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=122.0...140.00\text{ B}; V_{MM}=110.0\text{ B}; I_{pp}=3.4\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
EEP	TPSMC18A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=17.1...18.9\text{ B}; V_{MM}=15.3\text{ B}; I_{pp}=59.5\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
EF	SMBJ120C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10\text{ mA})=133.0...169.00\text{ B}; V_{MM}=120.0\text{ B}; I_{pp}=2.8\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
EFP	TPSMC20	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=18.0...22.0\text{ B}; V_{MM}=16.2\text{ B}; I_{pp}=51.5\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
EG	SMBJ120CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=133.0...153.00\text{ B}; V_{MM}=120.0\text{ B}; I_{pp}=3.1\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
EGP	TPSMC20A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=19.0...21.0\text{ B}; V_{MM}=17.1\text{ B}; I_{pp}=54.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
EH	SMBJ130C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=144.0...182.50\text{ B}; V_{MM}=130.0\text{ B}; I_{pp}=2.6\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
EHP	TPSMC22	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=19.8...24.2\text{ B}; V_{MM}=17.8\text{ B}; I_{pp}=47.0\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
EK	SMBJ130CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=144.0...165.50\text{ B}; V_{MM}=130.0\text{ B}; I_{pp}=2.9\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
EKP	TPSMC22A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=20.9...23.1\text{ B}; V_{MM}=18.8\text{ B}; I_{pp}=49.0\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
EL	SMBJ150C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=167.0...211.50\text{ B}; V_{MM}=150.0\text{ B}; I_{pp}=2.2\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
ELP	TPSMC24	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=21.6...26.4\text{ B}; V_{MM}=19.4\text{ B}; I_{pp}=43.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
EM	SMBJ150CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=167.0...192.50\text{ B}; V_{MM}=150.0\text{ B}; I_{pp}=2.5\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
EMP	TPSMC24A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=22.8...25.2\text{ B}; V_{MM}=20.5\text{ B}; I_{pp}=45.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*A
EN	SMBJ160C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=178.0...226.00\text{ B}; V_{MM}=160.0\text{ B}; I_{pp}=2.1\text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	К:1-2
ENP	TPSMC27	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 24.3...29.7 \text{ B}$; $V_{VM} = 21.8 \text{ B}$; $I_{PP} = 38.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
EP	SMBJ160CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 178.0...205.00 \text{ B}$; $V_{VM} = 160.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 2.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х*х
EPP	TPSMC27A	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 25.7...28.4 \text{ B}$; $V_{VM} = 23.1 \text{ B}$; $I_{PP} = 40.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
EQ	SMBJ170C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 189.0...239.50 \text{ B}$; $V_{VM} = 170.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 2.0 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х*х
EOP	TPSMC30	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 27.0...33.0 \text{ B}$; $V_{VM} = 24.3 \text{ B}$; $I_{PP} = 34.5 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
ER	SMBJ170CA	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 189.0...217.50 \text{ B}$; $V_{VM} = 170.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 2.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х*х
ERP	TPSMC30A	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 28.5...31.5 \text{ B}$; $V_{VM} = 25.6 \text{ B}$; $I_{PP} = 36.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
ESP	TPSMC33	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 29.7...36.3 \text{ B}$; $V_{VM} = 26.8 \text{ B}$; $I_{PP} = 31.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
ETP	TPSMC33A	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 31.4...34.7 \text{ B}$; $V_{VM} = 28.2 \text{ B}$; $I_{PP} = 32.8 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
EUP	TPSMC36	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 32.4...39.6 \text{ B}$; $V_{VM} = 29.1 \text{ B}$; $I_{PP} = 28.8 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
EVP	TPSMC36A	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 34.2...37.8 \text{ B}$; $V_{VM} = 30.8 \text{ B}$; $I_{PP} = 30.1 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
EWP	TPSMC39	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 35.1...42.9 \text{ B}$; $V_{VM} = 31.6 \text{ B}$; $I_{PP} = 26.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
EXP	TPSMC39A	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 37.1...41.0 \text{ B}$; $V_{VM} = 33.3 \text{ B}$; $I_{PP} = 27.8 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
EYP	TPSMC43	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 38.7...47.3 \text{ B}$; $V_{VM} = 34.8 \text{ B}$; $I_{PP} = 24.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
EZP	TPSMC43A	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 40.9...45.2 \text{ B}$; $V_{VM} = 36.8 \text{ B}$; $I_{PP} = 25.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FBB	SMCJ6.0CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.67...7.67 \text{ B}$; $V_{VM} = 6.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 145.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBC	SMCJ6.5CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 7.22...8.30 \text{ B}$; $V_{VM} = 6.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 133.9 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBCA	SMCJ5.0CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.40...7.25 \text{ B}$; $V_{VM} = 5.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 163.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBD	SMCJ8.5CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 9.44...10.82 \text{ B}$; $V_{VM} = 8.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 104.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBF	SMCJ10CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 11.10...14.10 \text{ B}$; $V_{VM} = 10.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 79.8 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBH	SMCJ12CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 13.30...16.90 \text{ B}$; $V_{VM} = 12.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 68.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBI	SMCJ13CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.40...18.20 \text{ B}$; $V_{VM} = 13.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 63.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBJ	SMCJ15CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.70...21.10 \text{ B}$; $V_{VM} = 15.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 55.8 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBL	SMCJ18CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20.00...25.30 \text{ B}$; $V_{VM} = 18.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 46.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBM	SMCJ20CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.20...25.50 \text{ B}$; $V_{VM} = 20.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 46.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBN	SMCJ22CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 24.40...28.00 \text{ B}$; $V_{VM} = 22.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 42.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBO	SMCJ24CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 26.70...30.70 \text{ B}$; $V_{VM} = 24.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 38.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBP	SMCJ26CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 28.90...33.20 \text{ B}$; $V_{VM} = 26.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 35.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBO	SMCJ28CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 31.10...35.80 \text{ B}$; $V_{VM} = 28.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 33.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBR	SMCJ30CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 33.30...42.40 \text{ B}$; $V_{VM} = 30.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 28.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBS	SMCJ33CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 36.70...42.20 \text{ B}$; $V_{VM} = 33.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 28.1 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBU	SMCJ40CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 44.40...51.10 \text{ B}$; $V_{VM} = 40.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 23.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBW	SMCJ48CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 53.30...61.30 \text{ B}$; $V_{VM} = 48.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 19.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FBZ	SMCJ58CA	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 64.40...74.60 \text{ B}$; $V_{VM} = 58.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 16.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	х*х
FUA	SMCJ5.0A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.40...7.25 \text{ B}$; $V_{VM} = 5.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 163.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUB	SMCJ6.0A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.67...7.67 \text{ B}$; $V_{VM} = 6.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 145.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUC	SMCJ6.5A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 7.22...8.30 \text{ B}$; $V_{VM} = 6.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 133.9 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUD	SMCJ8.5A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 9.44...10.82 \text{ B}$; $V_{VM} = 8.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 104.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUF	SMCJ10A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 11.10...12.80 \text{ B}$; $V_{VM} = 10.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 88.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUH	SMCJ12A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 13.30...15.30 \text{ B}$; $V_{VM} = 12.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 75.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUI	SMCJ13A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.40...16.50 \text{ B}$; $V_{VM} = 13.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 69.7 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUJ	SMCJ15A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.70...19.20 \text{ B}$; $V_{VM} = 15.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 61.5 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUL	SMCJ18A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20.00...23.30 \text{ B}$; $V_{VM} = 18.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 51.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUM	SMCJ20A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.20...28.10 \text{ B}$; $V_{VM} = 20.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 41.9 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUN	SMCJ22A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 24.40...28.00 \text{ B}$; $V_{VM} = 22.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 42.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUO	SMCJ24A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 26.70...30.70 \text{ B}$; $V_{VM} = 24.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 38.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUP	SMCJ26A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 28.90...36.80 \text{ B}$; $V_{VM} = 26.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 32.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUQ	SMCJ28A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 31.10...35.80 \text{ B}$; $V_{VM} = 28.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 33.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUR	SMCJ30A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 33.30...42.40 \text{ B}$; $V_{VM} = 30.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 28.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUS	SMCJ33A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 36.70...42.20 \text{ B}$; $V_{VM} = 33.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 28.1 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUJ	SMCJ40A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 44.40...51.10 \text{ B}$; $V_{VM} = 40.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 23.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUW	SMCJ48A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 53.30...61.30 \text{ B}$; $V_{VM} = 48.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 19.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
FUZ	SMCJ58A	STM	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 64.40...74.60 \text{ B}$; $V_{VM} = 58.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 16.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А



1 2

DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
GA	GF1A	VISH	dr	$V_R < 50 \text{ B}; I_R < 1 \text{ A}; V_F (I_F = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$	DO-214BA	K*А
GA	GF1A	GS	dr	$V_R < 50 \text{ B}; I_R < 1 \text{ A}; V_F (I_F = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$	DO-214BA	K*А
GB	GF1B	VISH	dr	$V_R < 100 \text{ B}; I_R < 1 \text{ A}; V_F (I_F = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$	DO-214BA	K*А
GB	GF1B	GS	dr	$V_R < 100 \text{ B}; I_R < 1 \text{ A}; V_F (I_F = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$	DO-214BA	K*А
GBB	SMCJ70CA	STM	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 77.80...89.50 \text{ B}; V_{VM} = 70.0 \text{ B}; I_{pp} = 13.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*xX
GBCA	SMCJ60CA	STM	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 66.70...76.70 \text{ B}; V_{VM} = 60.0 \text{ B}; I_{pp} = 15.5 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*xX
GBC	SMCJ85CA	STM	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 94.40...108.20 \text{ B}; V_{VM} = 85.0 \text{ B}; I_{pp} = 10.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*xX
GBG	SMCJ100CA	STM	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 111.00...141.00 \text{ B}; V_{VM} = 100.0 \text{ B}; I_{pp} = 8.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*xX
GBI	SMCJ130CA	STM	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 144.00...182.50 \text{ B}; V_{VM} = 130.0 \text{ B}; I_{pp} = 6.5 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*xX
GBL	SMCJ154CA	STM	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 171 \text{ B}; V_{VM} = 154.0 \text{ B}; I_{pp} = 6.1 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*xX
GBM	SMCJ170CA	STM	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 189.00...217.50 \text{ B}; V_{VM} = 170.0 \text{ B}; I_{pp} = 5.5 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*xX
GBN	SMCJ188CA	STM	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 209 \text{ B}; V_{VM} = 188.0 \text{ B}; I_{pp} = 4.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*xX
GD	GF1D	VISH	dr	$V_R < 200 \text{ B}; I_R < 1 \text{ A}; V_F (I_F = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$	DO-214BA	K*А
GD	GF1D	GS	dr	$V_R < 200 \text{ B}; I_R < 1 \text{ A}; V_F (I_F = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$	DO-214BA	K*А
GDD	SMCJ5.0	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.40...7.55 \text{ B}; V_{VM} = 5.0 \text{ B}; I_{pp} = 156.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDE	1SMC5.0AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.4...7.0 \text{ B}; V_{VM} = 9.2 \text{ B}; I_{pp} = 163 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDE	SMCJ5.0A	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.40...7.25 \text{ B}; V_{VM} = 5.0 \text{ B}; I_{pp} = 163.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDF	SMCJ6.0	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.67...8.45 \text{ B}; V_{VM} = 6.0 \text{ B}; I_{pp} = 131.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDF	1SMC6.0AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.67...7.37 \text{ B}; V_{VM} = 10.3 \text{ B}; I_{pp} = 145.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDG	SMCJ6.0A	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.67...7.67 \text{ B}; V_{VM} = 6.0 \text{ B}; I_{pp} = 145.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDH	SMCJ6.5	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 10.0 \text{ mA}) = 7.22...9.14 \text{ B}; V_{VM} = 6.5 \text{ B}; I_{pp} = 122.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDK	1SMC6.5AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 10.0 \text{ mA}) = 7.22...7.98 \text{ B}; V_{VM} = 11.2 \text{ B}; I_{pp} = 133.9 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDK	SMCJ6.5A	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 10.0 \text{ mA}) = 7.22...8.30 \text{ B}; V_{VM} = 6.5 \text{ B}; I_{pp} = 133.9 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDL	SMCJ7.0	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 10.0 \text{ mA}) = 7.78...9.86 \text{ B}; V_{VM} = 7.0 \text{ B}; I_{pp} = 112.8 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDM	1SMC7.0AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 10.0 \text{ mA}) = 7.78...8.6 \text{ B}; V_{VM} = 12 \text{ B}; I_{pp} = 125 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDM	SMCJ7.0A	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 10.0 \text{ mA}) = 7.78...8.95 \text{ B}; V_{VM} = 7.0 \text{ B}; I_{pp} = 125.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDN	SMCJ7.5	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 8.33...10.80 \text{ B}; V_{VM} = 7.5 \text{ B}; I_{pp} = 104.9 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDP	1SMC7.5AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 8.33...9.21 \text{ B}; V_{VM} = 12.9 \text{ B}; I_{pp} = 116.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDP	SMCJ7.5A	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 8.33...9.58 \text{ B}; V_{VM} = 7.5 \text{ B}; I_{pp} = 116.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDP	SMCJ8.0	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 8.89...11.30 \text{ B}; V_{VM} = 8.0 \text{ B}; I_{pp} = 100.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDR	1SMC8.0AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 8.89...9.83 \text{ B}; V_{VM} = 13.6 \text{ B}; I_{pp} = 110.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDR	SMCJ8.0A	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 8.89...10.23 \text{ B}; V_{VM} = 8.0 \text{ B}; I_{pp} = 110.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDS	SMCJ8.5	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 9.44...11.92 \text{ B}; V_{VM} = 8.5 \text{ B}; I_{pp} = 94.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDT	1SMC8.5AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 9.44...10.4 \text{ B}; V_{VM} = 14.4 \text{ B}; I_{pp} = 104.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDT	SMCJ8.5A	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 9.44...10.82 \text{ B}; V_{VM} = 8.5 \text{ B}; I_{pp} = 104.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDU	SMCJ9.0	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 10.00...12.80 \text{ B}; V_{VM} = 9.0 \text{ B}; I_{pp} = 88.7 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDV	1SMC9.0AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 10...11.1 \text{ B}; V_{VM} = 15.4 \text{ B}; I_{pp} = 97.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDV	SMCJ9.0A	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 10.00...11.50 \text{ B}; V_{VM} = 9.0 \text{ B}; I_{pp} = 97.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDW	SMCJ10	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 11.10...14.10 \text{ B}; V_{VM} = 10.0 \text{ B}; I_{pp} = 79.8 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDX	1SMC10AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 11.1...12.3 \text{ B}; V_{VM} = 17 \text{ B}; I_{pp} = 88.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDX	SMCJ10A	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 11.10...12.80 \text{ B}; V_{VM} = 10.0 \text{ B}; I_{pp} = 88.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDY	SMCJ11	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 12.20...15.40 \text{ B}; V_{VM} = 11.0 \text{ B}; I_{pp} = 74.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDZ	1SMC11AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 12.2...13.5 \text{ B}; V_{VM} = 18.2 \text{ B}; I_{pp} = 82.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GDZ	SMCJ11A	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 12.20...14.40 \text{ B}; V_{VM} = 11.0 \text{ B}; I_{pp} = 82.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GED	SMCJ12	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 13.30...16.90 \text{ B}; V_{VM} = 12.0 \text{ B}; I_{pp} = 68.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GEE	1SMC12AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 13.3...14.7 \text{ B}; V_{VM} = 19.9 \text{ B}; I_{pp} = 75.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GEE	SMCJ12A	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 13.30...15.30 \text{ B}; V_{VM} = 12.0 \text{ B}; I_{pp} = 75.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GEF	SMCJ13	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.40...18.20 \text{ B}; V_{VM} = 13.0 \text{ B}; I_{pp} = 63.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GEG	1SMC13AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.4...15.9 \text{ B}; V_{VM} = 21.5 \text{ B}; I_{pp} = 69.7 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GEG	SMCJ13A	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.40...16.50 \text{ B}; V_{VM} = 13.0 \text{ B}; I_{pp} = 69.7 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GEH	SMCJ14	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 15.60...19.80 \text{ B}; V_{VM} = 14.0 \text{ B}; I_{pp} = 58.1 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GEK	1SMC14AT3	ON	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 15.6...17.2 \text{ B}; V_{VM} = 23.2 \text{ B}; I_{pp} = 64.7 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GEK	SMCJ14A	VISH	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 15.60...17.90 \text{ B}; V_{VM} = 14.0 \text{ B}; I_{pp} = 64.7 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1-2
GEL	SMCJ15	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.70...21.10 \text{ B}; V_{VM} = 15.0 \text{ B}; I_{PP} = 55.8 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GEM	1SMC15AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.7...18.5 \text{ B}; V_{VM} = 24.4 \text{ B}; I_{PP} = 61.5 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GEM	SMCJ15A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.70...19.20 \text{ B}; V_{VM} = 15.0 \text{ B}; I_{PP} = 61.5 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GEN	SMCJ16	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.80...22.60 \text{ B}; V_{VM} = 16.0 \text{ B}; I_{PP} = 52.1 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GEP	1SMC16AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.8...19.7 \text{ B}; V_{VM} = 26 \text{ B}; I_{PP} = 57.7 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GEP	SMCJ16A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.80...20.50 \text{ B}; V_{VM} = 16.0 \text{ B}; I_{PP} = 57.7 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GEQ	SMCJ17	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 18.90...23.90 \text{ B}; V_{VM} = 17.0 \text{ B}; I_{PP} = 49.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GER	1SMC17AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 18.9...20.9 \text{ B}; V_{VM} = 27.6 \text{ B}; I_{PP} = 53.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GER	SMCJ17A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 18.90...21.70 \text{ B}; V_{VM} = 17.0 \text{ B}; I_{PP} = 53.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GES	SMCJ18	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20.00...25.30 \text{ B}; V_{VM} = 18.0 \text{ B}; I_{PP} = 46.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GET	1SMC18AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20...22.1 \text{ B}; V_{VM} = 29.2 \text{ B}; I_{PP} = 51.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GET	SMCJ18A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20.00...23.30 \text{ B}; V_{VM} = 18.0 \text{ B}; I_{PP} = 51.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GEU	SMCJ20	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.20...28.10 \text{ B}; V_{VM} = 20.0 \text{ B}; I_{PP} = 41.9 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GEV	1SMC20AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.2...24.5 \text{ B}; V_{VM} = 32.4 \text{ B}; I_{PP} = 46.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GEV	SMCJ20A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.20...25.50 \text{ B}; V_{VM} = 20.0 \text{ B}; I_{PP} = 46.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GEW	SMCJ22	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 24.40...30.90 \text{ B}; V_{VM} = 22.0 \text{ B}; I_{PP} = 38.1 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GEX	1SMC22AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 24.4...26.9 \text{ B}; V_{VM} = 35.5 \text{ B}; I_{PP} = 42.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GEX	SMCJ22A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 24.40...28.00 \text{ B}; V_{VM} = 22.0 \text{ B}; I_{PP} = 42.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GEY	SMCJ24	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 26.70...33.80 \text{ B}; V_{VM} = 24.0 \text{ B}; I_{PP} = 34.9 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GEZ	1SMC24AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 26.7...29.5 \text{ B}; V_{VM} = 38.9 \text{ B}; I_{PP} = 38.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GEZ	SMCJ24A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 26.70...30.70 \text{ B}; V_{VM} = 24.0 \text{ B}; I_{PP} = 38.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFD	SMCJ26	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 28.90...36.80 \text{ B}; V_{VM} = 26.0 \text{ B}; I_{PP} = 32.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFE	1SMC26AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 28.9...31.9 \text{ B}; V_{VM} = 42.1 \text{ B}; I_{PP} = 35.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFE	SMCJ26A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 28.90...33.20 \text{ B}; V_{VM} = 26.0 \text{ B}; I_{PP} = 35.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFF	SMCJ28	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 31.10...39.40 \text{ B}; V_{VM} = 28.0 \text{ B}; I_{PP} = 30.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFG	1SMC28AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 31.1...34.4 \text{ B}; V_{VM} = 45.4 \text{ B}; I_{PP} = 33 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFG	SMCJ28A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 31.10...35.80 \text{ B}; V_{VM} = 28.0 \text{ B}; I_{PP} = 33.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFH	SMCJ30	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 33.30...42.40 \text{ B}; V_{VM} = 30.0 \text{ B}; I_{PP} = 28.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFK	1SMC30AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 33.3...36.8 \text{ B}; V_{VM} = 48.4 \text{ B}; I_{PP} = 31 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFK	SMCJ30A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 33.30...38.30 \text{ B}; V_{VM} = 30.0 \text{ B}; I_{PP} = 31.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFL	SMCJ33	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 36.70...46.90 \text{ B}; V_{VM} = 33.0 \text{ B}; I_{PP} = 25.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFM	1SMC33AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 36.7...40.6 \text{ B}; V_{VM} = 53.3 \text{ B}; I_{PP} = 28.1 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFM	SMCJ33A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 36.70...42.20 \text{ B}; V_{VM} = 33.0 \text{ B}; I_{PP} = 28.1 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFN	SMCJ36	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 40.00...50.70 \text{ B}; V_{VM} = 36.0 \text{ B}; I_{PP} = 23.3 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFP	1SMC36AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 40.0...44.2 \text{ B}; V_{VM} = 58.1 \text{ B}; I_{PP} = 25.8 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFP	SMCJ36A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 40.00...46.00 \text{ B}; V_{VM} = 36.0 \text{ B}; I_{PP} = 25.8 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFO	SMCJ40	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 44.40...56.30 \text{ B}; V_{VM} = 40.0 \text{ B}; I_{PP} = 21.0 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFR	1SMC40AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 44.4...49.1 \text{ B}; V_{VM} = 64.5 \text{ B}; I_{PP} = 32.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFR	SMCJ40A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 44.40...51.10 \text{ B}; V_{VM} = 40.0 \text{ B}; I_{PP} = 23.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFS	SMCJ43	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 47.80...60.50 \text{ B}; V_{VM} = 43.0 \text{ B}; I_{PP} = 19.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFT	1SMC43AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 47.8...52.8 \text{ B}; V_{VM} = 69.4 \text{ B}; I_{PP} = 21.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFT	SMCJ43A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 47.80...54.90 \text{ B}; V_{VM} = 43.0 \text{ B}; I_{PP} = 21.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFU	SMCJ45	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 50.00...63.30 \text{ B}; V_{VM} = 45.0 \text{ B}; I_{PP} = 18.7 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFV	1SMC45AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 50.0...55.3 \text{ B}; V_{VM} = 72.2 \text{ B}; I_{PP} = 20.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFV	SMCJ45A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 50.00...57.50 \text{ B}; V_{VM} = 45.0 \text{ B}; I_{PP} = 20.6 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFW	SMCJ48	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 53.30...67.50 \text{ B}; V_{VM} = 48.0 \text{ B}; I_{PP} = 17.5 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFX	1SMC48AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 53.3...58.9 \text{ B}; V_{VM} = 77.4 \text{ B}; I_{PP} = 19.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFX	SMCJ48A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 53.30...61.30 \text{ B}; V_{VM} = 48.0 \text{ B}; I_{PP} = 19.4 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFY	SMCJ51	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 56.70...71.80 \text{ B}; V_{VM} = 51.0 \text{ B}; I_{PP} = 16.5 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFZ	1SMC51AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 56.7...62.7 \text{ B}; V_{VM} = 82.4 \text{ B}; I_{PP} = 18.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GFZ	SMCJ51A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 56.70...65.20 \text{ B}; V_{VM} = 51.0 \text{ B}; I_{PP} = 18.2 \text{ A}$	DO-214AB, SMC	К*А
GG	GF1G	VISH	dr	$V_A < 400 \text{ B}; I_C < 1 \text{ A}; V_T (I_C = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$	DO-214BA	К*А
GG	GF1G	GS	dr	$V_A < 400 \text{ B}; I_C < 1 \text{ A}; V_T (I_C = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$	DO-214BA	К*А

**DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
GGD	SMCJ54	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=60.00\dots76.00\text{ B}; V_{WM}=54.0\text{ B}; I_{pp}=15.6\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGE	1SMC54AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=60.0\dots66.3\text{ B}; V_{WM}=87.1\text{ B}; I_{pp}=17.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGE	SMCJ54A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=60.00\dots69.00\text{ B}; V_{WM}=54.0\text{ B}; I_{pp}=17.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGF	SMCJ58	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=64.40\dots81.60\text{ B}; V_{WM}=58.0\text{ B}; I_{pp}=14.6\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGG	1SMC58AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=64.4\dots71.2\text{ B}; V_{WM}=93.6\text{ B}; I_{pp}=16.0\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGG	SMCJ58A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=64.40\dots74.60\text{ B}; V_{WM}=58.0\text{ B}; I_{pp}=16.0\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGH	SMCJ60	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=66.70\dots84.50\text{ B}; V_{WM}=60.0\text{ B}; I_{pp}=14.0\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGK	1SMC60AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=66.7\dots73.7\text{ B}; V_{WM}=96.8\text{ B}; I_{pp}=15.5\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGK	SMCJ60A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=66.70\dots76.70\text{ B}; V_{WM}=60.0\text{ B}; I_{pp}=15.5\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGL	SMCJ64	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=71.10\dots90.10\text{ B}; V_{WM}=64.0\text{ B}; I_{pp}=13.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGM	1SMC64AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=71.1\dots78.6\text{ B}; V_{WM}=103\text{ B}; I_{pp}=14.6\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGM	SMCJ64A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=71.10\dots81.80\text{ B}; V_{WM}=64.0\text{ B}; I_{pp}=14.6\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGN	SMCJ70	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=77.80\dots98.60\text{ B}; V_{WM}=70.0\text{ B}; I_{pp}=12.0\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGP	1SMC70AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=77.8\dots86\text{ B}; V_{WM}=113\text{ B}; I_{pp}=13.3\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGP	SMCJ70A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=77.80\dots89.50\text{ B}; V_{WM}=70.0\text{ B}; I_{pp}=13.3\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGQ	SMCJ75	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=83.30\dots106.00\text{ B}; V_{WM}=75.0\text{ B}; I_{pp}=11.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGR	1SMC75AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=83.3\dots92.1\text{ B}; V_{WM}=121\text{ B}; I_{pp}=12.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGR	SMCJ75A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=83.30\dots95.80\text{ B}; V_{WM}=75.0\text{ B}; I_{pp}=12.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGS	SMCJ78	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=86.70\dots110.00\text{ B}; V_{WM}=78.0\text{ B}; I_{pp}=10.8\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGT	1SMC78AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=86.7\dots95.8\text{ B}; V_{WM}=126\text{ B}; I_{pp}=11.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGT	SMCJ78A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=86.70\dots99.70\text{ B}; V_{WM}=78.0\text{ B}; I_{pp}=11.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGU	SMCJ85	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=94.40\dots119.20\text{ B}; V_{WM}=85.0\text{ B}; I_{pp}=9.9\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGV	SMCJ85A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=94.40\dots108.20\text{ B}; V_{WM}=85.0\text{ B}; I_{pp}=10.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGW	SMCJ90	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=100.00\dots126.50\text{ B}; V_{WM}=90.0\text{ B}; I_{pp}=9.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGX	SMCJ90A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=100.00\dots115.50\text{ B}; V_{WM}=90.0\text{ B}; I_{pp}=10.3\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGY	SMCJ100	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=111.00\dots141.00\text{ B}; V_{WM}=100.0\text{ B}; I_{pp}=8.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GGZ	SMCJ100A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=111.00\dots128.00\text{ B}; V_{WM}=100.0\text{ B}; I_{pp}=9.3\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GHD	SMCJ110	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=122.00\dots154.50\text{ B}; V_{WM}=110.0\text{ B}; I_{pp}=7.7\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GHE	SMCJ110A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=122.00\dots140.50\text{ B}; V_{WM}=110.0\text{ B}; I_{pp}=8.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GHF	SMCJ120	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=133.00\dots169.00\text{ B}; V_{WM}=120.0\text{ B}; I_{pp}=7.0\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GHG	SMCJ120A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=133.00\dots153.00\text{ B}; V_{WM}=120.0\text{ B}; I_{pp}=7.9\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GHH	SMCJ130	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=144.00\dots182.50\text{ B}; V_{WM}=130.0\text{ B}; I_{pp}=6.5\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GHK	SMCJ130A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=144.00\dots165.50\text{ B}; V_{WM}=130.0\text{ B}; I_{pp}=7.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GHL	SMCJ150	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=167.00\dots211.50\text{ B}; V_{WM}=150.0\text{ B}; I_{pp}=5.6\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GHM	SMCJ150A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=167.00\dots192.50\text{ B}; V_{WM}=150.0\text{ B}; I_{pp}=6.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GHN	SMCJ160	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=178.00\dots226.00\text{ B}; V_{WM}=160.0\text{ B}; I_{pp}=5.2\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GHP	SMCJ160A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=178.00\dots205.00\text{ B}; V_{WM}=160.0\text{ B}; I_{pp}=5.8\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GHQ	SMCJ170	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=189.00\dots239.50\text{ B}; V_{WM}=170.0\text{ B}; I_{pp}=4.9\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GHR	SMCJ170A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=189.00\dots217.50\text{ B}; V_{WM}=170.0\text{ B}; I_{pp}=5.5\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GJ	GF1J	VISH	dr	$V_R < 600\text{ B}; I_T < 1\text{ A}; V_F(I_T=1\text{ A}) < 1.1\text{ B}$	DO-214BA	K*А
GJ	GF1J	GS	dr	$V_R < 600\text{ B}; I_T < 1\text{ A}; V_F(I_T=1\text{ A}) < 1.1\text{ B}$	DO-214BA	K*А
GK	GF1K	VISH	dr	$V_R < 800\text{ B}; I_T < 1\text{ A}; V_F(I_T=1\text{ A}) < 1.2\text{ B}$	DO-214BA	K*А
GK	GF1K	GS	dr	$V_R < 800\text{ B}; I_T < 1\text{ A}; V_F(I_T=1\text{ A}) < 1.2\text{ B}$	DO-214BA	K*А
GM	GF1M	VISH	dr	$V_R < 1000\text{ B}; I_T < 1\text{ A}; V_F(I_T=1\text{ A}) < 1.2\text{ B}$	DO-214BA	K*А
GM	GF1M	GS	dr	$V_R < 1000\text{ B}; I_T < 1\text{ A}; V_F(I_T=1\text{ A}) < 1.2\text{ B}$	DO-214BA	K*А
GJA	SMCJ60A	STM	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=66.70\dots76.70\text{ B}; V_{WM}=60.0\text{ B}; I_{pp}=15.5\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GJB	SMCJ70A	STM	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=77.80\dots89.50\text{ B}; V_{WM}=70.0\text{ B}; I_{pp}=13.3\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GJE	SMCJ85A	STM	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=94.40\dots108.20\text{ B}; V_{WM}=85.0\text{ B}; I_{pp}=10.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GJG	SMCJ100A	STM	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=111.00\dots141.00\text{ B}; V_{WM}=100.0\text{ B}; I_{pp}=8.4\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GJI	SMCJ130A	STM	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=144.00\dots182.50\text{ B}; V_{WM}=130.0\text{ B}; I_{pp}=6.5\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GJL	SMCJ154A	STM	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=171\text{ B}; V_{WM}=154.0\text{ B}; I_{pp}=6.1\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GJM	SMCJ170A	STM	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=189.00\dots217.50\text{ B}; V_{WM}=170.0\text{ B}; I_{pp}=5.5\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А
GJN	SMCJ188A	STM	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=209\text{ B}; V_{WM}=188.0\text{ B}; I_{pp}=4.6\text{ A}$	DO-214AB, SMC	K*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1-2
HD	SMAJ5.0	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.40 \dots 7.30 \text{ B}$; $V_{VM} = 9.6 \text{ B}$; $I_{PP} = 41.6 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HE	SMAJ5.0A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.4 \dots 7.0 \text{ B}$; $V_{VM} = 9.2 \text{ B}$; $I_{PP} = 43.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HF	SMAJ6.0	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.67 \dots 8.15 \text{ B}$; $V_{VM} = 11.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 35.1 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HG	SMAJ6.0A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.67 \dots 7.37 \text{ B}$; $V_{VM} = 10.3 \text{ B}$; $I_{PP} = 38.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HH	SMAJ6.5	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 7.22 \dots 8.82 \text{ B}$; $V_{VM} = 12.3 \text{ B}$; $I_{PP} = 32.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HK	SMAJ6.5A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 7.22 \dots 7.98 \text{ B}$; $V_{VM} = 11.2 \text{ B}$; $I_{PP} = 35.7 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HL	SMAJ7.0	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 7.78 \dots 9.51 \text{ B}$; $V_{VM} = 13.3 \text{ B}$; $I_{PP} = 30.1 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HM	SMAJ7.0A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 7.78 \dots 8.60 \text{ B}$; $V_{VM} = 12.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 33.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HN	SMAJ7.5	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 8.33 \dots 10.3 \text{ B}$; $V_{VM} = 14.3 \text{ B}$; $I_{PP} = 28.0 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HP	SMAJ7.5A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 8.33 \dots 9.21 \text{ B}$; $V_{VM} = 12.9 \text{ B}$; $I_{PP} = 31.0 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HQ	SMAJ8.0	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 8.89 \dots 10.9 \text{ B}$; $V_{VM} = 15.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 26.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HR	SMAJ8.0A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 8.89 \dots 9.83 \text{ B}$; $V_{VM} = 13.6 \text{ B}$; $I_{PP} = 29.4 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HS	SMAJ8.5	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 9.44 \dots 11.5 \text{ B}$; $V_{VM} = 15.9 \text{ B}$; $I_{PP} = 25.1 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HT	SMAJ8.5A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 9.44 \dots 10.4 \text{ B}$; $V_{VM} = 14.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 27.7 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HU	SMAJ9.0	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 10.0 \dots 12.2 \text{ B}$; $V_{VM} = 16.9 \text{ B}$; $I_{PP} = 23.6 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HV	SMAJ9.0A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 10.0 \dots 11.1 \text{ B}$; $V_{VM} = 15.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 26.0 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HW	SMAJ10	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 11.1 \dots 13.6 \text{ B}$; $V_{VM} = 18.8 \text{ B}$; $I_{PP} = 21.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HX	SMAJ10A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 11.1 \dots 12.3 \text{ B}$; $V_{VM} = 17.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 23.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HY	SMAJ11	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 12.2 \dots 14.9 \text{ B}$; $V_{VM} = 20.1 \text{ B}$; $I_{PP} = 20.0 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
HZ	SMAJ11A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 12.2 \dots 13.5 \text{ B}$; $V_{VM} = 18.2 \text{ B}$; $I_{PP} = 22.0 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
ID	SMAJ12	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 13.3 \dots 16.3 \text{ B}$; $V_{VM} = 22.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 18.1 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IE	SMAJ12A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 13.3 \dots 14.7 \text{ B}$; $V_{VM} = 19.9 \text{ B}$; $I_{PP} = 20.1 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IF	SMAJ13	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.4 \dots 17.6 \text{ B}$; $V_{VM} = 23.8 \text{ B}$; $I_{PP} = 16.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IG	SMAJ13A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.4 \dots 15.9 \text{ B}$; $V_{VM} = 21.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 18.6 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IH	SMAJ14	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 15.6 \dots 19.1 \text{ B}$; $V_{VM} = 25.8 \text{ B}$; $I_{PP} = 15.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IK	SMAJ14A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 15.6 \dots 17.2 \text{ B}$; $V_{VM} = 23.2 \text{ B}$; $I_{PP} = 17.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IL	SMAJ15	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.7 \dots 20.4 \text{ B}$; $V_{VM} = 26.9 \text{ B}$; $I_{PP} = 14.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IM	SMAJ15A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.7 \dots 18.5 \text{ B}$; $V_{VM} = 24.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 16.4 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IN	SMAJ16	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.8 \dots 21.8 \text{ B}$; $V_{VM} = 28.8 \text{ B}$; $I_{PP} = 13.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IO	SMAJ16A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.8 \dots 19.7 \text{ B}$; $V_{VM} = 26.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 15.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IP	SMAJ17	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 18.9 \dots 23.1 \text{ B}$; $V_{VM} = 30.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 13.1 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IR	SMAJ17A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 18.9 \dots 20.9 \text{ B}$; $V_{VM} = 27.6 \text{ B}$; $I_{PP} = 14.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IS	SMAJ18	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20.0 \dots 24.4 \text{ B}$; $V_{VM} = 32.2 \text{ B}$; $I_{PP} = 12.4 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IT	SMAJ18A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20.0 \dots 22.1 \text{ B}$; $V_{VM} = 29.2 \text{ B}$; $I_{PP} = 13.7 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IU	SMAJ20	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.2 \dots 27.1 \text{ B}$; $V_{VM} = 35.8 \text{ B}$; $I_{PP} = 11.1 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IV	SMAJ20A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.2 \dots 24.5 \text{ B}$; $V_{VM} = 32.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 12.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IW	SMAJ22	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 24.4 \dots 29.8 \text{ B}$; $V_{VM} = 39.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 10.1 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IX	SMAJ22A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 24.4 \dots 26.9 \text{ B}$; $V_{VM} = 35.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 11.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IY	SMAJ24	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 26.7 \dots 32.6 \text{ B}$; $V_{VM} = 43.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 9.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
IZ	SMAJ24A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 26.7 \dots 29.5 \text{ B}$; $V_{VM} = 38.9 \text{ B}$; $I_{PP} = 10.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
JD	SMAJ26	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 28.9 \dots 31.9 \text{ B}$; $V_{VM} = 46.6 \text{ B}$; $I_{PP} = 8.6 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
JE	SMAJ26A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 28.9 \dots 25.3 \text{ B}$; $V_{VM} = 42.1 \text{ B}$; $I_{PP} = 9.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
JF	SMAJ28	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 31.1 \dots 38.0 \text{ B}$; $V_{VM} = 50.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 8.0 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
JG	SMAJ28A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 31.1 \dots 34.4 \text{ B}$; $V_{VM} = 45.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 8.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
JH	SMAJ30	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 33.3 \dots 40.7 \text{ B}$; $V_{VM} = 53.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 7.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
JK	SMAJ30A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 33.3 \dots 36.8 \text{ B}$; $V_{VM} = 48.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 8.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
JL	SMAJ33	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 36.7 \dots 44.9 \text{ B}$; $V_{VM} = 59.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
JM	SMAJ33A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 36.7 \dots 40.6 \text{ B}$; $V_{VM} = 53.3 \text{ B}$; $I_{PP} = 7.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
JN	SMAJ36	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 40.0 \dots 48.9 \text{ B}$; $V_{VM} = 64.3 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
JO	SMAJ36A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 40.0 \dots 44.2 \text{ B}$; $V_{VM} = 58.1 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.9 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
JP	SMAJ40	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 44.4 \dots 54.3 \text{ B}$; $V_{VM} = 71.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.6 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
JR	SMAJ40A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 44.4 \dots 49.1 \text{ B}$; $V_{VM} = 64.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
JS	SMAJ43	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 47.8 \dots 58.4 \text{ B}$; $V_{VM} = 76.7 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А



1 2

DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
JT	SMAJ43A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=47.8...52.8\text{ B}; V_{MM}=69.4\text{ B}; I_{pp}=5.7\text{ A}$	DO-2144C, SMA	K*А
JU	SMAJ45	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=50.0...61.1\text{ B}; V_{MM}=80.3\text{ B}; I_{pp}=5.0\text{ A}$	DO-2144C, SMA	K*А
JV	SMAJ45A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=50.0...55.3\text{ B}; V_{MM}=72.7\text{ B}; I_{pp}=5.5\text{ A}$	DO-2144C, SMA	K*А
JW	SMAJ48	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=53.3...65.1\text{ B}; V_{MM}=85.5\text{ B}; I_{pp}=4.7\text{ A}$	DO-2144C, SMA	K*А
JX	SMAJ48A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=53.3...58.9\text{ B}; V_{MM}=77.4\text{ B}; I_{pp}=5.2\text{ A}$	DO-2144C, SMA	K*А
JY	SMAJ51	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=56.7...69.3\text{ B}; V_{MM}=91.1\text{ B}; I_{pp}=4.4\text{ A}$	DO-2144C, SMA	K*А
JZ	SMAJ51A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=56.7...62.7\text{ B}; V_{MM}=82.4\text{ B}; I_{pp}=4.9\text{ A}$	DO-2144C, SMA	K*А
KD	SMBJ5.0	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.40...7.55\text{ B}; V_{MM}=5.0\text{ B}; I_{pp}=62.5\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KDP	TPSMB6.8	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.12...7.48\text{ B}; V_{MM}=5.50\text{ B}; I_{pp}=55.6\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KE	1SMB5.0AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.4...7.0\text{ B}; V_{MM}=9.2\text{ B}; I_{pp}=65.2\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KE	SMBJ5.0A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.40...7.23\text{ B}; V_{MM}=5.0\text{ B}; I_{pp}=65.2\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KEP	TPSMB6.8A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.45...7.14\text{ B}; V_{MM}=5.80\text{ B}; I_{pp}=57.1\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KF	SMBJ6.0	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.67...8.45\text{ B}; V_{MM}=6.0\text{ B}; I_{pp}=52.6\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KFP	TPSMB7.5	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.75...8.25\text{ B}; V_{MM}=6.05\text{ B}; I_{pp}=51.3\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KG	1SMB6.0AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.67...7.37\text{ B}; V_{MM}=10.3\text{ B}; I_{pp}=58.3\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KG	SMBJ6.0A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.67...7.67\text{ B}; V_{MM}=6.0\text{ B}; I_{pp}=58.3\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KGP	TPSMB7.5A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.13...7.88\text{ B}; V_{MM}=6.40\text{ B}; I_{pp}=53.1\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KH	SMBJ6.5	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.22...9.14\text{ B}; V_{MM}=6.5\text{ B}; I_{pp}=48.7\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KHP	TPSMB8.2	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.38...9.02\text{ B}; V_{MM}=6.63\text{ B}; I_{pp}=48.0\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KK	1SMB6.5AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.22...7.98\text{ B}; V_{MM}=11.2\text{ B}; I_{pp}=53.6\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KK	SMBJ6.5A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.22...8.30\text{ B}; V_{MM}=6.5\text{ B}; I_{pp}=53.6\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KKP	TPSMB8.2A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.79...8.61\text{ B}; V_{MM}=7.02\text{ B}; I_{pp}=49.6\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KL	SMBJ7.0	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.78...9.86\text{ B}; V_{MM}=7.0\text{ B}; I_{pp}=45.1\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KLP	TPSMB9.1	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.19...10.0\text{ B}; V_{MM}=7.37\text{ B}; I_{pp}=43.5\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KM	1SMB7.0AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.78...8.6\text{ B}; V_{MM}=12.0\text{ B}; I_{pp}=50.0\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KM	SMBJ7.0A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.78...8.95\text{ B}; V_{MM}=7.0\text{ B}; I_{pp}=50.0\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KMP	TPSMB9.1A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.65...9.55\text{ B}; V_{MM}=7.78\text{ B}; I_{pp}=44.8\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KN	SMBJ7.5	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.33...10.80\text{ B}; V_{MM}=7.5\text{ B}; I_{pp}=42.0\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KNP	TPSMB10	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.00...11.0\text{ B}; V_{MM}=8.10\text{ B}; I_{pp}=40.0\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KP	1SMB7.5AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.33...9.21\text{ B}; V_{MM}=12.9\text{ B}; I_{pp}=46.5\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KP	SMBJ7.5A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.33...9.58\text{ B}; V_{MM}=7.5\text{ B}; I_{pp}=46.5\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KPP	TPSMB10A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.50...10.5\text{ B}; V_{MM}=8.55\text{ B}; I_{pp}=41.4\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KQP	SMBJ8.0	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.89...11.30\text{ B}; V_{MM}=8.0\text{ B}; I_{pp}=40.0\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KQP	TPSMB11	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.90...12.1\text{ B}; V_{MM}=8.92\text{ B}; I_{pp}=37.0\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KR	1SMB8.0AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.89...9.83\text{ B}; V_{MM}=13.6\text{ B}; I_{pp}=44.1\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KR	SMBJ8.0A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.89...10.23\text{ B}; V_{MM}=8.0\text{ B}; I_{pp}=44.1\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KRP	TPSMB11A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=10.5...11.6\text{ B}; V_{MM}=9.40\text{ B}; I_{pp}=38.5\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KS	SMBJ8.5	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.44...11.92\text{ B}; V_{MM}=8.5\text{ B}; I_{pp}=37.7\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KSP	TPSMB12	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=10.8...13.2\text{ B}; V_{MM}=9.72\text{ B}; I_{pp}=34.7\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KT	1SMB8.5AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.44...10.4\text{ B}; V_{MM}=14.4\text{ B}; I_{pp}=41.7\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KT	SMBJ8.5A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.44...10.82\text{ B}; V_{MM}=8.5\text{ B}; I_{pp}=41.7\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KTP	TPSMB12A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.4...12.6\text{ B}; V_{MM}=10.2\text{ B}; I_{pp}=35.9\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KU	SMBJ9.0	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=10.00...12.80\text{ B}; V_{MM}=9.0\text{ B}; I_{pp}=35.5\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KUP	TPSMB13	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.7...14.3\text{ B}; V_{MM}=10.5\text{ B}; I_{pp}=31.6\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KV	1SMB9.0AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=10.0...11.1\text{ B}; V_{MM}=15.4\text{ B}; I_{pp}=39\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KV	SMBJ9.0A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=10.00...11.50\text{ B}; V_{MM}=9.0\text{ B}; I_{pp}=39.0\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KVP	TPSMB13A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=12.4...13.7\text{ B}; V_{MM}=11.1\text{ B}; I_{pp}=33.0\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KW	SMBJ10	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.0...14.10\text{ B}; V_{MM}=10.0\text{ B}; I_{pp}=31.9\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KWP	TPSMB15	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=13.5...16.5\text{ B}; V_{MM}=12.1\text{ B}; I_{pp}=27.3\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KX	1SMB10AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.1...12.3\text{ B}; V_{MM}=17\text{ B}; I_{pp}=35.3\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KX	SMBJ10A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.0...12.80\text{ B}; V_{MM}=10.0\text{ B}; I_{pp}=35.3\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А
KXC	1SMB10CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.1...12.27\text{ B}; V_{MM}=17\text{ B}; I_{pp}=35.3\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*x
KXP	TPSMB15A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=14.3...15.8\text{ B}; V_{MM}=12.8\text{ B}; I_{pp}=28.3\text{ A}$	DO-2144A, SMB	K*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1-2
KY	SMBJ11	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 12.20 \dots 15.40 \text{ B}; V_{VM} = 11.0 \text{ B}; I_{PP} = 29.9 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
KYP	TPSMB16	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.4 \dots 17.6 \text{ B}; V_{VM} = 12.9 \text{ B}; I_{PP} = 25.5 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
KZ	1SMB11AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 12.2 \dots 13.5 \text{ B}; V_{VM} = 18.2 \text{ B}; I_{PP} = 33 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
KZ	SMBJ11A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 12.20 \dots 14.40 \text{ B}; V_{VM} = 11.0 \text{ B}; I_{PP} = 33.0 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
KZC	1SMB11CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 12.2 \dots 13.5 \text{ B}; V_{VM} = 18.2 \text{ B}; I_{PP} = 33 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
KZP	TPSMB16A	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 15.2 \dots 16.8 \text{ B}; V_{VM} = 13.6 \text{ B}; I_{PP} = 26.7 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LD	SMBJ12	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 13.30 \dots 16.90 \text{ B}; V_{VM} = 12.0 \text{ B}; I_{PP} = 27.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LDP	TPSMB18	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.2 \dots 19.8 \text{ B}; V_{VM} = 14.5 \text{ B}; I_{PP} = 22.6 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LE	1SMB12AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 13.3 \dots 14.7 \text{ B}; V_{VM} = 19.9 \text{ B}; I_{PP} = 30.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LE	SMBJ12A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 13.30 \dots 15.30 \text{ B}; V_{VM} = 12.0 \text{ B}; I_{PP} = 30.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LEC	1SMB12CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 13.3 \dots 14.7 \text{ B}; V_{VM} = 19.9 \text{ B}; I_{PP} = 30.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
LFP	TPSMB18A	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.1 \dots 18.9 \text{ B}; V_{VM} = 15.3 \text{ B}; I_{PP} = 23.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LEP	SMBJ13	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.40 \dots 18.20 \text{ B}; V_{VM} = 13.0 \text{ B}; I_{PP} = 25.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LFP	TPSMB20	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 18.0 \dots 22.0 \text{ B}; V_{VM} = 16.2 \text{ B}; I_{PP} = 20.6 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LG	1SMB13AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.4 \dots 15.9 \text{ B}; V_{VM} = 21.5 \text{ B}; I_{PP} = 27.9 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LG	SMBJ13A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.40 \dots 16.50 \text{ B}; V_{VM} = 13.0 \text{ B}; I_{PP} = 27.9 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LGC	1SMB13CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 14.4 \dots 15.9 \text{ B}; V_{VM} = 21.5 \text{ B}; I_{PP} = 27.9 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
LH	SMBJ14	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 15.60 \dots 19.80 \text{ B}; V_{VM} = 14.0 \text{ B}; I_{PP} = 23.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LHP	TPSMB22	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 19.8 \dots 24.2 \text{ B}; V_{VM} = 17.8 \text{ B}; I_{PP} = 18.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LK	1SMB14AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 15.6 \dots 17.2 \text{ B}; V_{VM} = 23.2 \text{ B}; I_{PP} = 25.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LK	SMBJ14A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 15.60 \dots 17.90 \text{ B}; V_{VM} = 14.0 \text{ B}; I_{PP} = 25.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LKC	1SMB14CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 15.6 \dots 17.2 \text{ B}; V_{VM} = 23.2 \text{ B}; I_{PP} = 25.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
LKP	TPSMB22A	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20.9 \dots 23.1 \text{ B}; V_{VM} = 18.8 \text{ B}; I_{PP} = 19.6 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LL	SMBJ15	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.70 \dots 21.10 \text{ B}; V_{VM} = 15.0 \text{ B}; I_{PP} = 22.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LLP	TPSMB24	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 21.6 \dots 26.4 \text{ B}; V_{VM} = 19.4 \text{ B}; I_{PP} = 17.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LM	1SMB15AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.7 \dots 18.5 \text{ B}; V_{VM} = 24.4 \text{ B}; I_{PP} = 24 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LM	SMBJ15A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.70 \dots 19.20 \text{ B}; V_{VM} = 15.0 \text{ B}; I_{PP} = 24.0 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LMC	1SMB15CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.7 \dots 18.5 \text{ B}; V_{VM} = 24.4 \text{ B}; I_{PP} = 24 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
LMP	TPSMB24A	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.8 \dots 25.2 \text{ B}; V_{VM} = 20.5 \text{ B}; I_{PP} = 18.1 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LN	SMBJ16	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.80 \dots 22.60 \text{ B}; V_{VM} = 16.0 \text{ B}; I_{PP} = 20.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LNP	TPSMB27	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 24.3 \dots 29.7 \text{ B}; V_{VM} = 21.8 \text{ B}; I_{PP} = 15.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LP	1SMB16AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.8 \dots 19.7 \text{ B}; V_{VM} = 26 \text{ B}; I_{PP} = 23.1 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LP	SMBJ16A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.80 \dots 20.50 \text{ B}; V_{VM} = 16.0 \text{ B}; I_{PP} = 23.1 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LPC	1SMB16CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.8 \dots 19.7 \text{ B}; V_{VM} = 26 \text{ B}; I_{PP} = 23.1 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
LPP	TPSMB27A	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 25.7 \dots 28.4 \text{ B}; V_{VM} = 23.1 \text{ B}; I_{PP} = 16.0 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LQ	SMBJ17	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 18.90 \dots 23.90 \text{ B}; V_{VM} = 17.0 \text{ B}; I_{PP} = 19.7 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LOP	TPSMB30	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 27.0 \dots 33.0 \text{ B}; V_{VM} = 24.3 \text{ B}; I_{PP} = 13.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LR	1SMB17AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 18.9 \dots 20.9 \text{ B}; V_{VM} = 27.6 \text{ B}; I_{PP} = 21.7 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LR	SMBJ17A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 18.90 \dots 21.70 \text{ B}; V_{VM} = 17.0 \text{ B}; I_{PP} = 21.7 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LRC	1SMB17CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 18.9 \dots 20.9 \text{ B}; V_{VM} = 27.6 \text{ B}; I_{PP} = 21.7 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
LRP	TPSMB30A	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 28.5 \dots 31.5 \text{ B}; V_{VM} = 25.6 \text{ B}; I_{PP} = 14.5 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LS	SMBJ18	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20.00 \dots 25.30 \text{ B}; V_{VM} = 18.0 \text{ B}; I_{PP} = 18.6 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LSP	TPSMB33	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 29.7 \dots 36.3 \text{ B}; V_{VM} = 26.8 \text{ B}; I_{PP} = 12.6 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LT	1SMB18AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20.0 \dots 22.1 \text{ B}; V_{VM} = 29.2 \text{ B}; I_{PP} = 20.5 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LT	SMBJ18A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20.00 \dots 23.30 \text{ B}; V_{VM} = 18.0 \text{ B}; I_{PP} = 20.5 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LTC	1SMB18CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20.0 \dots 22.1 \text{ B}; V_{VM} = 29.2 \text{ B}; I_{PP} = 20.5 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
LTP	TPSMB33A	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 31.4 \dots 34.7 \text{ B}; V_{VM} = 28.2 \text{ B}; I_{PP} = 13.1 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LU	SMBJ20	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.20 \dots 28.10 \text{ B}; V_{VM} = 20.0 \text{ B}; I_{PP} = 16.7 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LUP	TPSMB36	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 32.4 \dots 39.6 \text{ B}; V_{VM} = 29.1 \text{ B}; I_{PP} = 11.5 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LV	1SMB20AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.2 \dots 24.5 \text{ B}; V_{VM} = 32.4 \text{ B}; I_{PP} = 18.5 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LV	SMBJ20A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.20 \dots 25.50 \text{ B}; V_{VM} = 20.0 \text{ B}; I_{PP} = 18.5 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
LVC	1SMB20CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.2 \dots 24.5 \text{ B}; V_{VM} = 32.4 \text{ B}; I_{PP} = 18.5 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	x*x
LVP	TPSMB36A	GS	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 34.2 \dots 37.8 \text{ B}; V_{VM} = 30.8 \text{ B}; I_{PP} = 12.0 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А



DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
LW	SMBJ22	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=24.40\text{...}30.90\text{ B}$; $V_{MM}=22.0\text{ B}$; $I_{pp}=15.2\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
LWP	TPSMB39	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=35.1\text{...}42.9\text{ B}$; $V_{MM}=31.6\text{ B}$; $I_{pp}=10.6\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
LX	1SMB22AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=24.4\text{...}26.9\text{ B}$; $V_{MM}=35.5\text{ B}$; $I_{pp}=16.9\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
LX	SMBJ22A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=24.40\text{...}28.00\text{ B}$; $V_{MM}=22.0\text{ B}$; $I_{pp}=16.9\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
LXC	1SMB22CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=24.4\text{...}26.9\text{ B}$; $V_{MM}=35.5\text{ B}$; $I_{pp}=16.9\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*x
LXP	TPSMB39A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=37.1\text{...}41.0\text{ B}$; $V_{MM}=33.3\text{ B}$; $I_{pp}=11.1\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
LY	SMBJ24	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=26.70\text{...}33.80\text{ B}$; $V_{MM}=24.0\text{ B}$; $I_{pp}=14.0\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
LYP	TPSMB43	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=38.7\text{...}47.3\text{ B}$; $V_{MM}=34.8\text{ B}$; $I_{pp}=9.7\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
LZ	1SMB24AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=26.7\text{...}29.5\text{ B}$; $V_{MM}=38.9\text{ B}$; $I_{pp}=15.4\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
LZ	SMBJ24A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=26.70\text{...}30.70\text{ B}$; $V_{MM}=24.0\text{ B}$; $I_{pp}=15.4\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
LZC	1SMB24CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=26.7\text{...}29.5\text{ B}$; $V_{MM}=38.9\text{ B}$; $I_{pp}=15.4\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*x
LZP	TPSMB43A	GS	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=40.9\text{...}45.2\text{ B}$; $V_{MM}=36.8\text{ B}$; $I_{pp}=10.1\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MD	SMBJ26	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=28.90\text{...}36.80\text{ B}$; $V_{MM}=26.0\text{ B}$; $I_{pp}=12.4\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
ME	1SMB26AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=28.9\text{...}31.9\text{ B}$; $V_{MM}=42.1\text{ B}$; $I_{pp}=14.2\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
ME	SMBJ26A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=28.90\text{...}33.20\text{ B}$; $V_{MM}=26.0\text{ B}$; $I_{pp}=14.2\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MEE	1SMB26CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=28.9\text{...}31.9\text{ B}$; $V_{MM}=42.1\text{ B}$; $I_{pp}=14.2\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*x
MF	SMBJ28	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=31.10\text{...}39.40\text{ B}$; $V_{MM}=28.0\text{ B}$; $I_{pp}=12.0\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MG	1SMB28AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=31.1\text{...}34.4\text{ B}$; $V_{MM}=45.4\text{ B}$; $I_{pp}=13.2\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MG	SMBJ28A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=31.10\text{...}35.80\text{ B}$; $V_{MM}=28.0\text{ B}$; $I_{pp}=13.2\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MGC	1SMB28CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=31.1\text{...}34.4\text{ B}$; $V_{MM}=45.4\text{ B}$; $I_{pp}=13.2\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*x
MH	SMB30	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=33.30\text{...}42.20\text{ B}$; $V_{MM}=30.0\text{ B}$; $I_{pp}=11.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
MK	1SMB30AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=33.3\text{...}36.8\text{ B}$; $V_{MM}=48.4\text{ B}$; $I_{pp}=12.4\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MK	SMBJ30A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=33.30\text{...}38.30\text{ B}$; $V_{MM}=30.0\text{ B}$; $I_{pp}=12.4\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MKC	1SMB30CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=33.3\text{...}36.8\text{ B}$; $V_{MM}=48.4\text{ B}$; $I_{pp}=12.4\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*x
ML	SMBJ33	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=36.70\text{...}46.90\text{ B}$; $V_{MM}=33.0\text{ B}$; $I_{pp}=10.2\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MM	1SMB33AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=36.7\text{...}40.6\text{ B}$; $V_{MM}=53.3\text{ B}$; $I_{pp}=11.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MM	SMBJ33A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=36.70\text{...}42.20\text{ B}$; $V_{MM}=33.0\text{ B}$; $I_{pp}=11.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MMC	1SMB33CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=36.7\text{...}40.6\text{ B}$; $V_{MM}=53.3\text{ B}$; $I_{pp}=11.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*x
MN	SMBJ36	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=40.00\text{...}50.70\text{ B}$; $V_{MM}=36.0\text{ B}$; $I_{pp}=9.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MP	1SMB36AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=40.0\text{...}44.2\text{ B}$; $V_{MM}=58.1\text{ B}$; $I_{pp}=10.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MP	SMBJ36A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=40.00\text{...}46.00\text{ B}$; $V_{MM}=36.0\text{ B}$; $I_{pp}=10.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MPC	1SMB36CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=40.0\text{...}44.2\text{ B}$; $V_{MM}=58.1\text{ B}$; $I_{pp}=10.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*x
MQ	SMBJ40	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=44.40\text{...}56.30\text{ B}$; $V_{MM}=40.0\text{ B}$; $I_{pp}=8.4\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MR	1SMB40AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=44.4\text{...}49.1\text{ B}$; $V_{MM}=64.5\text{ B}$; $I_{pp}=9.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MR	SMBJ40A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=44.40\text{...}51.10\text{ B}$; $V_{MM}=40.0\text{ B}$; $I_{pp}=9.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MRC	1SMB40CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=44.4\text{...}49.1\text{ B}$; $V_{MM}=64.5\text{ B}$; $I_{pp}=9.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*x
MS	SMBJ43	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=47.80\text{...}60.50\text{ B}$; $V_{MM}=43.0\text{ B}$; $I_{pp}=7.8\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MT	1SMB43AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=47.8\text{...}52.8\text{ B}$; $V_{MM}=69.4\text{ B}$; $I_{pp}=8.6\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MT	SMBJ43A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=47.80\text{...}54.90\text{ B}$; $V_{MM}=43.0\text{ B}$; $I_{pp}=8.6\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MTC	1SMB43CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=47.8\text{...}52.8\text{ B}$; $V_{MM}=69.4\text{ B}$; $I_{pp}=8.6\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*x
MU	SMBJ45	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=50.00\text{...}63.30\text{ B}$; $V_{MM}=45.0\text{ B}$; $I_{pp}=7.5\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MV	1SMB45AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=50.0\text{...}55.3\text{ B}$; $V_{MM}=72.7\text{ B}$; $I_{pp}=8.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MV	SMBJ45A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=50.00\text{...}57.50\text{ B}$; $V_{MM}=45.0\text{ B}$; $I_{pp}=8.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MVC	1SMB45CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=50.0\text{...}55.3\text{ B}$; $V_{MM}=72.7\text{ B}$; $I_{pp}=8.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*x
MW	SMBJ48	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=53.30\text{...}67.50\text{ B}$; $V_{MM}=48.0\text{ B}$; $I_{pp}=7.0\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MX	1SMB48AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=53.3\text{...}58.9\text{ B}$; $V_{MM}=77.4\text{ B}$; $I_{pp}=7.7\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MX	SMBJ48A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=53.30\text{...}61.30\text{ B}$; $V_{MM}=48.0\text{ B}$; $I_{pp}=7.7\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MXC	1SMB48CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=53.3\text{...}58.9\text{ B}$; $V_{MM}=77.4\text{ B}$; $I_{pp}=7.7\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*x
MY	SMBJ51	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=56.70\text{...}71.80\text{ B}$; $V_{MM}=51.0\text{ B}$; $I_{pp}=6.6\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MZ	1SMB51AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=56.7\text{...}62.7\text{ B}$; $V_{MM}=82.4\text{ B}$; $I_{pp}=7.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MZ	SMBJ51A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=56.70\text{...}65.20\text{ B}$; $V_{MM}=51.0\text{ B}$; $I_{pp}=7.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А
MZC	1SMB51CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=56.7\text{...}62.7\text{ B}$; $V_{MM}=82.4\text{ B}$; $I_{pp}=7.3\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*x
ND	SMBJ54	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=60.00\text{...}76.00\text{ B}$; $V_{MM}=54.0\text{ B}$; $I_{pp}=6.2\text{ A}$	DO-214AA, SMB	K*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1-2
NE	1SMB54AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 60.0...66.3 \text{ B}$; $V_{VM} = 87.1 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.9 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NE	SMBJ54A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 60.00...69.00 \text{ B}$; $V_{VM} = 54.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.9 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NEC	1SMB54CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 60.0...66.3 \text{ B}$; $V_{VM} = 87.1 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.9 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х*х
NF	SMBJ58	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 64.40...81.60 \text{ B}$; $V_{VM} = 58.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NG	1SMB58AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 64.4...71.2 \text{ B}$; $V_{VM} = 93.6 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.4 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NG	SMBJ58A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 64.40...74.60 \text{ B}$; $V_{VM} = 58.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.4 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NGC	1SMB58CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 64.4...71.18 \text{ B}$; $V_{VM} = 93.6 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.4 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NH	SMBJ60	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 66.70...84.50 \text{ B}$; $V_{VM} = 60.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.6 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NK	1SMB60AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 66.7...73.7 \text{ B}$; $V_{VM} = 96.8 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NK	SMBJ60A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 66.70...76.70 \text{ B}$; $V_{VM} = 60.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NKC	1SMB60CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 66.7...73.72 \text{ B}$; $V_{VM} = 96.8 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х*х
NL	SMBJ64	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 71.10...90.10 \text{ B}$; $V_{VM} = 64.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NM	1SMB64AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 71.1...78.6 \text{ B}$; $V_{VM} = 103 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NM	SMBJ64A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 71.10...81.80 \text{ B}$; $V_{VM} = 64.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NMC	1SMB64CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 71.1...78.58 \text{ B}$; $V_{VM} = 103 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х*х
NN	SMBJ70	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 77.80...98.60 \text{ B}$; $V_{VM} = 70.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NP	1SMB70AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 77.8...86 \text{ B}$; $V_{VM} = 113 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NP	SMBJ70A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 77.80...89.50 \text{ B}$; $V_{VM} = 70.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NPC	1SMB70CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 77.8...85.99 \text{ B}$; $V_{VM} = 113 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х*х
NQ	SMBJ75	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 83.30...106.00 \text{ B}$; $V_{VM} = 75.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.5 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NR	1SMB75AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 83.3...92.1 \text{ B}$; $V_{VM} = 121 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.9 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NR	SMBJ75A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 83.30...95.80 \text{ B}$; $V_{VM} = 75.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.9 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NRC	1SMB75CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 83.3...92.07 \text{ B}$; $V_{VM} = 121 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.9 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х*х
NS	SMBJ78	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 86.70...110.00 \text{ B}$; $V_{VM} = 78.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NT	1SMB78AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 86.7...95.83 \text{ B}$; $V_{VM} = 126 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.7 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NT	SMBJ78A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 86.70...99.70 \text{ B}$; $V_{VM} = 78.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.7 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NTC	1SMB78CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 86.7...95.83 \text{ B}$; $V_{VM} = 126 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.7 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	х*х
NU	SMBJ85	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 94.40...119.20 \text{ B}$; $V_{VM} = 85.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.9 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NV	1SMB85AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 94.4...104 \text{ B}$; $V_{VM} = 137 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.4 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NV	SMBJ85A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 94.40...108.20 \text{ B}$; $V_{VM} = 85.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.4 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NW	SMBJ90	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 100.0...126.50 \text{ B}$; $V_{VM} = 90.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NX	1SMB90AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 100...111 \text{ B}$; $V_{VM} = 146 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.1 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NX	SMBJ90A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 100.0...115.50 \text{ B}$; $V_{VM} = 90.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.1 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NY	SMBJ100	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 111.0...141.00 \text{ B}$; $V_{VM} = 100.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.4 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NZ	1SMB100AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 111...123 \text{ B}$; $V_{VM} = 162 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.7 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
NZ	SMBJ100A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 111.0...128.00 \text{ B}$; $V_{VM} = 100.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.7 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
PD	SMBJ110	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 122.0...154.50 \text{ B}$; $V_{VM} = 110.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.0 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
PE	1SMB110AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 122...135 \text{ B}$; $V_{VM} = 177 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.4 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
PE	SMBJ110A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 122.0...140.00 \text{ B}$; $V_{VM} = 110.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.4 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
PF	SMBJ120	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 133.0...169.00 \text{ B}$; $V_{VM} = 120.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 2.8 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
PG	1SMB120AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 133...147 \text{ B}$; $V_{VM} = 193 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.1 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
PG	SMBJ120A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 133.0...153.00 \text{ B}$; $V_{VM} = 120.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.1 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
PH	SMBJ130	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 144.0...182.50 \text{ B}$; $V_{VM} = 130.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 2.6 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
PK	1SMB130AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 144...159 \text{ B}$; $V_{VM} = 209 \text{ B}$; $I_{PP} = 2.9 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
PK	SMBJ130A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 144.0...165.50 \text{ B}$; $V_{VM} = 130.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 2.9 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
PL	SMBJ150	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 167.0...211.50 \text{ B}$; $V_{VM} = 150.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 2.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
PM	1SMB150AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 167...185 \text{ B}$; $V_{VM} = 243 \text{ B}$; $I_{PP} = 2.5 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
PM	SMBJ150A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 167.0...192.50 \text{ B}$; $V_{VM} = 150.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 2.5 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
PN	SMBJ160	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 178.0...226.00 \text{ B}$; $V_{VM} = 160.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 2.1 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
PP	1SMB160AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 178...197 \text{ B}$; $V_{VM} = 259 \text{ B}$; $I_{PP} = 2.3 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
PR	1SMB170AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 189...209 \text{ B}$; $V_{VM} = 275 \text{ B}$; $I_{PP} = 2.2 \text{ A}$	DO-214AA, SMB	К*А
QE	1SMA5.0AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.4...7.0 \text{ B}$; $V_{VM} = 9.2 \text{ B}$; $I_{PP} = 43.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А
QG	1SMA6.0AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 10.0 \text{ mA}) = 6.67...7.37 \text{ B}$; $V_{VM} = 10.3 \text{ B}$; $I_{PP} = 38.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*А



DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
OK	1SMA6.5AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.22...7.98\text{ B}; V_{MM}=11.2\text{ B}; I_{pp}=35.7\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
OM	1SMA7.0AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.78...8.6\text{ B}; V_{MM}=12.0\text{ B}; I_{pp}=33.3\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
OP	1SMA7.5AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.33...9.21\text{ B}; V_{MM}=12.9\text{ B}; I_{pp}=31.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
OR	1SMA8.0AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.89...9.83\text{ B}; V_{MM}=13.6\text{ B}; I_{pp}=29.4\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
OT	1SMA8.5AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.44...10.4\text{ B}; V_{MM}=14.4\text{ B}; I_{pp}=27.8\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
OV	1SMA9.0AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=10...11.1\text{ B}; V_{MM}=15.4\text{ B}; I_{pp}=26.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
OX	1SMA1.0AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.1...12.3\text{ B}; V_{MM}=17.0\text{ B}; I_{pp}=23.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
QXC	1SMA10CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.1...12.27\text{ B}; V_{MM}=17.0\text{ B}; I_{pp}=23.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
QZ	1SMA11AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=12.2...13.5\text{ B}; V_{MM}=18.2\text{ B}; I_{pp}=22.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
QZC	1SMA11CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=12.2...13.48\text{ B}; V_{MM}=18.2\text{ B}; I_{pp}=22.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
RA	RGF1A	VISH	dr	$V_R < 50\text{ B}; I_C < 1\text{ A}; V_F(I_F=1\text{ A}) < 1.3\text{ B}; C_0=8.5\text{ нФ}$	DO-214BA	K*А
RB	RGF1B	VISH	dr	$V_R < 100\text{ B}; I_C < 1\text{ A}; V_F(I_F=1\text{ A}) < 1.3\text{ B}; C_0=8.5\text{ нФ}$	DO-214BA	K*А
RD	RGF1D	VISH	dr	$V_R < 200\text{ B}; I_C < 1\text{ A}; V_F(I_F=1\text{ A}) < 1.3\text{ B}; C_0=8.5\text{ нФ}$	DO-214BA	K*А
RD	SMAJ54	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=60.0...73.3\text{ B}; V_{MM}=96.3\text{ B}; I_{pp}=4.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RE	1SMA12AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=13.3...14.7\text{ B}; V_{MM}=19.9\text{ B}; I_{pp}=20.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RE	SMAJ54A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=60.0...66.3\text{ B}; V_{MM}=87.1\text{ B}; I_{pp}=4.6\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
REC	1SMA12CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=13.3...14.7\text{ B}; V_{MM}=19.9\text{ B}; I_{pp}=20.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
RF	SMAJ58	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=64.4...78.7\text{ B}; V_{MM}=103\text{ B}; I_{pp}=3.9\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RG	1SMA13AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=14.4...15.9\text{ B}; V_{MM}=21.5\text{ B}; I_{pp}=18.6\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RG	RGF1G	VISH	dr	$V_R < 400\text{ B}; I_C < 1\text{ A}; V_F(I_F=1\text{ A}) < 1.3\text{ B}; C_0=8.5\text{ нФ}$	DO-214BA	K*А
RG	SMAJ58A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=64.4...71.2\text{ B}; V_{MM}=93.6\text{ B}; I_{pp}=4.3\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RGC	1SMA13CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=14.4...15.92\text{ B}; V_{MM}=21.5\text{ B}; I_{pp}=18.6\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
RH	SMAJ60	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=66.7...81.5\text{ B}; V_{MM}=107\text{ B}; I_{pp}=3.7\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RJ	RGF1J	VISH	dr	$V_R < 600\text{ B}; I_C < 1\text{ A}; V_F(I_F=1\text{ A}) < 1.3\text{ B}; C_0=8.5\text{ нФ}$	DO-214BA	K*А
RK	1SMA14AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=15.6...17.24\text{ B}; V_{MM}=23.2\text{ B}; I_{pp}=17.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RK	RGF1K	VISH	dr	$V_R < 800\text{ B}; I_C < 1\text{ A}; V_F(I_F=1\text{ A}) < 1.3\text{ B}; C_0=8.5\text{ нФ}$	DO-214BA	K*А
RK	SMAJ60A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=66...73.7\text{ B}; V_{MM}=96.8\text{ B}; I_{pp}=4.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RKC	1SMA14CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=15.6...17.24\text{ B}; V_{MM}=23.2\text{ B}; I_{pp}=17.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
RL	SMAJ64	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=71.1...86.4\text{ B}; V_{MM}=114\text{ B}; I_{pp}=3.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RM	1SMA15AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=16.7...18.5\text{ B}; V_{MM}=24.4\text{ B}; I_{pp}=16.4\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RM	RGF1M	VISH	dr	$V_R < 1000\text{ B}; I_C < 1\text{ A}; V_F(I_F=1\text{ A}) < 1.3\text{ B}; C_0=8.5\text{ нФ}$	DO-214BA	K*А
RM	SMAJ64A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=71.1...78.6\text{ B}; V_{MM}=103\text{ B}; I_{pp}=3.9\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RMC	1SMA15CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=16.7...18.46\text{ B}; V_{MM}=24.4\text{ B}; I_{pp}=16.4\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
RN	SMAJ70	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=77.8...95.1\text{ B}; V_{MM}=125\text{ B}; I_{pp}=3.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RP	1SMA16AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=17.8...19.7\text{ B}; V_{MM}=26.0\text{ B}; I_{pp}=15.4\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RP	SMAJ70A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=77.8...86.0\text{ B}; V_{MM}=113\text{ B}; I_{pp}=3.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RPBF	MMT05B230T3	ON	TSPD	$V_{BR}=190\text{ B}; I_{pps} > 50\text{ A}; C_T < 75\text{ нФ}$	DO-214AA, SMB	K*А
RPBG	MMT05B260T3	ON	TSPD	$V_{BR}=240\text{ B}; I_{pps} > 50\text{ A}; C_T < 75\text{ нФ}$	DO-214AA, SMB	K*А
RPBJ	MMT05B310T3	ON	TSPD	$V_{BR}=280\text{ B}; I_{pps} > 50\text{ A}; C_T < 75\text{ нФ}$	DO-214AA, SMB	K*А
RPC	1SMA16CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=17.8...19.67\text{ B}; V_{MM}=26.0\text{ B}; I_{pp}=15.4\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
RPDF	MMT10B230T3	ON	TSPD	$V_{BR}=190\text{ B}; I_{pps} > 100\text{ A}; C_T < 200\text{ нФ}$	DO-214AA, SMB	K*А
RPDG	MMT10B260T3	ON	TSPD	$V_{BR}=240\text{ B}; I_{pps} > 100\text{ A}; C_T < 200\text{ нФ}$	DO-214AA, SMB	K*А
RPDJ	MMT10B310T3	ON	TSPD	$V_{BR}=280\text{ B}; I_{pps} > 100\text{ A}; C_T < 200\text{ нФ}$	DO-214AA, SMB	K*А
RQ	SMAJ75	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=83.3...102\text{ B}; V_{MM}=134\text{ B}; I_{pp}=3.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RR	1SMA17AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=18.9...20.9\text{ B}; V_{MM}=27.6\text{ B}; I_{pp}=14.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RR	SMAJ75A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=83.3...92.1\text{ B}; V_{MM}=121\text{ B}; I_{pp}=3.3\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RRC	1SMA17CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=18.9...20.9\text{ B}; V_{MM}=27.6\text{ B}; I_{pp}=14.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
RS	SMAJ78	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=86.7...106\text{ B}; V_{MM}=139\text{ B}; I_{pp}=2.9\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RT	1SMA18AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=20...22.1\text{ B}; V_{MM}=29.2\text{ B}; I_{pp}=13.7\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RT	SMAJ78A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=86.7...95.8\text{ B}; V_{MM}=126\text{ B}; I_{pp}=2.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RTC	1SMA18CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=20...22.11\text{ B}; V_{MM}=29.2\text{ B}; I_{pp}=13.7\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
RU	SMAJ85	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=94.4...115\text{ B}; V_{MM}=151\text{ B}; I_{pp}=2.6\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А
RV	1SMA20AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=22.2...24.5\text{ B}; V_{MM}=32.4\text{ B}; I_{pp}=12.3\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	К:1-2
RV	SMAJ85A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 94.4...104 \text{ B}$; $V_{WM} = 137 \text{ B}$; $I_{pp} = 2.9 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
RVC	1SMA20CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.2...24.54 \text{ B}$; $V_{WM} = 32.4 \text{ B}$; $I_{pp} = 12.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	х•х
RW	SMAJ90	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 100...122 \text{ B}$; $V_{WM} = 160 \text{ B}$; $I_{pp} = 2.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
RX	1SMA22AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 24.4...26.9 \text{ B}$; $V_{WM} = 35.5 \text{ B}$; $I_{pp} = 11.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
RX	SMAJ90A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 100...111 \text{ B}$; $V_{WM} = 146 \text{ B}$; $I_{pp} = 2.7 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
RXC	1SMA22CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 24.4...26.97 \text{ B}$; $V_{WM} = 35.5 \text{ B}$; $I_{pp} = 11.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	х•х
RY	SMAJ100	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 111...136 \text{ B}$; $V_{WM} = 179 \text{ B}$; $I_{pp} = 2.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
RZ	1SMA24AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 26.7...29.5 \text{ B}$; $V_{WM} = 38.9 \text{ B}$; $I_{pp} = 10.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
RZ	SMAJ100A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 111...123 \text{ B}$; $V_{WM} = 162 \text{ B}$; $I_{pp} = 2.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
RZC	1SMA24CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 26.7...29.51 \text{ B}$; $V_{WM} = 38.9 \text{ B}$; $I_{pp} = 10.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	х•х
S1A	S1A	FAIR	dr	$V_{R} < 50 \text{ B}$; $I_T < 1 \text{ A}$; $V_T (I_T = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$	DO-214AC, SMA	К•А
S1A	SMB4001	MCC	dr	$V_{R} < 50 \text{ B}$; $I_T = 1 \text{ A}$; $V_T (I_T = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$; $C_0 = 12 \text{ нФ}$	DO-214AA, SMB	К•А
S1B	S1B	FAIR	dr	$V_{R} < 100 \text{ B}$; $I_T < 1 \text{ A}$; $V_T (I_T = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$	DO-214AC, SMA	К•А
S1B	SMB4002	MCC	dr	$V_{R} < 100 \text{ B}$; $I_T = 1 \text{ A}$; $V_T (I_T = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$; $C_0 = 12 \text{ нФ}$	DO-214AA, SMB	К•А
S1D	S1D	FAIR	dr	$V_{R} < 200 \text{ B}$; $I_T < 1 \text{ A}$; $V_T (I_T = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$	DO-214AC, SMA	К•А
S1D	SMB4003	MCC	dr	$V_{R} < 200 \text{ B}$; $I_T = 1 \text{ A}$; $V_T (I_T = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$; $C_0 = 12 \text{ нФ}$	DO-214AA, SMB	К•А
S1G	S1G	FAIR	dr	$V_{R} < 400 \text{ B}$; $I_T < 1 \text{ A}$; $V_T (I_T = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$	DO-214AC, SMA	К•А
S1G	SMB4004	MCC	dr	$V_{R} < 400 \text{ B}$; $I_T = 1 \text{ A}$; $V_T (I_T = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$; $C_0 = 12 \text{ нФ}$	DO-214AA, SMB	К•А
S1J	S1J	FAIR	dr	$V_{R} < 600 \text{ B}$; $I_T < 1 \text{ A}$; $V_T (I_T = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$	DO-214AC, SMA	К•А
S1J	SMB4005	MCC	dr	$V_{R} < 600 \text{ B}$; $I_T = 1 \text{ A}$; $V_T (I_T = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$; $C_0 = 12 \text{ нФ}$	DO-214AA, SMB	К•А
S1K	S1K	FAIR	dr	$V_{R} < 800 \text{ B}$; $I_T < 1 \text{ A}$; $V_T (I_T = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$	DO-214AC, SMA	К•А
S1K	SMB4006	MCC	dr	$V_{R} < 800 \text{ B}$; $I_T = 1 \text{ A}$; $V_T (I_T = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$; $C_0 = 12 \text{ нФ}$	DO-214AA, SMB	К•А
S1M	S1M	FAIR	dr	$V_{R} < 1000 \text{ B}$; $I_T < 1 \text{ A}$; $V_T (I_T = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$	DO-214AC, SMA	К•А
S1M	SMB4007	MCC	dr	$V_{R} < 1000 \text{ B}$; $I_T = 1 \text{ A}$; $V_T (I_T = 1 \text{ A}) < 1.1 \text{ B}$; $C_0 = 12 \text{ нФ}$	DO-214AA, SMB	К•А
SD	SMAJ110	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 122...149 \text{ B}$; $V_{WM} = 196 \text{ B}$; $I_{pp} = 2.0 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SE	1SMA26AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 28.9...31.9 \text{ B}$; $V_{WM} = 42.1 \text{ B}$; $I_{pp} = 9.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SE	SMAJ110A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 122...135 \text{ B}$; $V_{WM} = 177 \text{ B}$; $I_{pp} = 2.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SEC	1SMA26CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 28.9...31.94 \text{ B}$; $V_{WM} = 42.1 \text{ B}$; $I_{pp} = 9.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	х•х
SF	SMAJ120	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 133...163 \text{ B}$; $V_{WM} = 214 \text{ B}$; $I_{pp} = 1.9 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SG	1SMA28AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 31.1...34.4 \text{ B}$; $V_{WM} = 45.4 \text{ B}$; $I_{pp} = 8.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SG	SMAJ120A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 133...147 \text{ B}$; $V_{WM} = 193 \text{ B}$; $I_{pp} = 2.0 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SGC	1SMA28CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 31.1...34.37 \text{ B}$; $V_{WM} = 45.4 \text{ B}$; $I_{pp} = 8.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	х•х
SH	SMAJ130	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 144...176 \text{ B}$; $V_{WM} = 231 \text{ B}$; $I_{pp} = 1.7 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SK	1SMA30AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 33.3...36.8 \text{ B}$; $V_{WM} = 48.4 \text{ B}$; $I_{pp} = 8.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SK	SMAJ130A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 144...159 \text{ B}$; $V_{WM} = 209 \text{ B}$; $I_{pp} = 1.9 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SKC	1SMA30CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 33.3...36.81 \text{ B}$; $V_{WM} = 48.4 \text{ B}$; $I_{pp} = 8.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	х•х
SL	SMAJ150	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 167...204 \text{ B}$; $V_{WM} = 268 \text{ B}$; $I_{pp} = 1.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SM	1SMA33AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 36.7...40.6 \text{ B}$; $V_{WM} = 53.3 \text{ B}$; $I_{pp} = 7.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SM	SMAJ150A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 167...185 \text{ B}$; $V_{WM} = 243 \text{ B}$; $I_{pp} = 1.6 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SMC	1SMA33CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 36.7...40.56 \text{ B}$; $V_{WM} = 53.3 \text{ B}$; $I_{pp} = 7.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	х•х
SN	SMAJ160	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 178...218 \text{ B}$; $V_{WM} = 287 \text{ B}$; $I_{pp} = 1.4 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SN	1SMA36AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 40...44.2 \text{ B}$; $V_{WM} = 58.1 \text{ B}$; $I_{pp} = 6.9 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SP	SMAJ160A	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 178...197 \text{ B}$; $V_{WM} = 259 \text{ B}$; $I_{pp} = 1.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SQC	1SMA36CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 40...44.21 \text{ B}$; $V_{WM} = 58.1 \text{ B}$; $I_{pp} = 6.9 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	х•х
SQ	SMAJ170	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 189...231 \text{ B}$; $V_{WM} = 304 \text{ B}$; $I_{pp} = 1.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SR	1SMA40AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 44...49.1 \text{ B}$; $V_{WM} = 64.5 \text{ B}$; $I_{pp} = 6.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SR	SMAJ170	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 189...209 \text{ B}$; $V_{WM} = 275 \text{ B}$; $I_{pp} = 1.4 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SRC	1SMA40CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 44...49.07 \text{ B}$; $V_{WM} = 64.5 \text{ B}$; $I_{pp} = 6.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	х•х
ST	1SMA43AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 47.8...52.8 \text{ B}$; $V_{WM} = 69.4 \text{ B}$; $I_{pp} = 5.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
STC	1SMA43CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 47.8...52.83 \text{ B}$; $V_{WM} = 69.4 \text{ B}$; $I_{pp} = 5.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	х•х
SV	1SMA45AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 50...55.3 \text{ B}$; $V_{WM} = 72.2 \text{ B}$; $I_{pp} = 5.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А
SVC	1SMA45CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 50...55.3 \text{ B}$; $V_{WM} = 72.2 \text{ B}$; $I_{pp} = 5.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	х•х
SX	1SMA48AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 53.3...58.9 \text{ B}$; $V_{WM} = 77.4 \text{ B}$; $I_{pp} = 5.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	К•А



DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
SXC	1SMA48CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=53.3...58.91\text{ B}; V_{MM}=77.4\text{ B}; I_{pp}=5.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
SZ	1SMA51AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=56.7...62.7\text{ B}; V_{MM}=82.4\text{ B}; I_{pp}=4.9\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
SZC	1SMA51CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=56.7...62.67\text{ B}; V_{MM}=82.4\text{ B}; I_{pp}=4.9\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TD	SMAJ5.0C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.40...7.30\text{ B}; V_{MM}=9.6\text{ B}; I_{pp}=41.6\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TE	1SMA54AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=60...66.3\text{ B}; V_{MM}=87.1\text{ B}; I_{pp}=4.6\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
TE	SMAJ5.0AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.4...7.0\text{ B}; V_{MM}=9.2\text{ B}; I_{pp}=43.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TEC	1SMA54CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=60...66.32\text{ B}; V_{MM}=87.1\text{ B}; I_{pp}=4.6\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TF	SMAJ6.0C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.67...8.15\text{ B}; V_{MM}=11.4\text{ B}; I_{pp}=35.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TG	1SMA58AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=64.4...71.5\text{ B}; V_{MM}=93.6\text{ B}; I_{pp}=4.3\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
TG	SMAJ6.0AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=6.67...7.37\text{ B}; V_{MM}=10.3\text{ B}; I_{pp}=38.8\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TGC	1SMA58CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=64.4...71.5\text{ B}; V_{MM}=93.6\text{ B}; I_{pp}=4.3\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TH	SMAJ6.5C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.22...8.82\text{ B}; V_{MM}=12.3\text{ B}; I_{pp}=32.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TK	1SMA60AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=66.7...73.7\text{ B}; V_{MM}=96.8\text{ B}; I_{pp}=4.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
TK	SMAJ6.5AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.22...7.98\text{ B}; V_{MM}=11.2\text{ B}; I_{pp}=35.7\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TKC	1SMA60CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=66.7...73.72\text{ B}; V_{MM}=96.8\text{ B}; I_{pp}=4.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TL	SMAJ7.0C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.78...9.51\text{ B}; V_{MM}=13.3\text{ B}; I_{pp}=30.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TM	1SMA64AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=71.1...78.6\text{ B}; V_{MM}=103\text{ B}; I_{pp}=3.9\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
TM	SMAJ7.0AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=7.78...8.60\text{ B}; V_{MM}=12.0\text{ B}; I_{pp}=33.3\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TMC	1SMA64CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=71.1...78.58\text{ B}; V_{MM}=103\text{ B}; I_{pp}=3.9\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TN	SMAJ7.5C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.33...10.3\text{ B}; V_{MM}=14.3\text{ B}; I_{pp}=28.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TP	1SMA70AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=77.8...86\text{ B}; V_{MM}=113\text{ B}; I_{pp}=3.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
TP	SMAJ7.5AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=10.0\text{ mA})=8.33...9.21\text{ B}; V_{MM}=12.9\text{ B}; I_{pp}=31.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TPC	1SMA70CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=77.8...85.99\text{ B}; V_{MM}=113\text{ B}; I_{pp}=3.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TQ	SMAJ8.0C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.89...10.9\text{ B}; V_{MM}=15.0\text{ B}; I_{pp}=26.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TR	1SMA75AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=83.3...92.1\text{ B}; V_{MM}=121\text{ B}; I_{pp}=3.3\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
TR	SMAJ8.0AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=8.89...9.83\text{ B}; V_{MM}=13.6\text{ B}; I_{pp}=29.4\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TRC	1SMA75CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=83.3...92.1\text{ B}; V_{MM}=121\text{ B}; I_{pp}=3.3\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TS	1SMA78AT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=86.7...95.83\text{ B}; V_{MM}=126\text{ B}; I_{pp}=3.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	K*A
TS	SMAJ8.5C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.44...11.5\text{ B}; V_{MM}=15.9\text{ B}; I_{pp}=25.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TSC	1SMA78CAT3	ON	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=86.7...95.83\text{ B}; V_{MM}=126\text{ B}; I_{pp}=3.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TT	SMAJ8.5AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=9.44...10.4\text{ B}; V_{MM}=14.4\text{ B}; I_{pp}=27.7\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TU	SMAJ9.0C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=10.0...12.2\text{ B}; V_{MM}=16.9\text{ B}; I_{pp}=23.6\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TV	SMAJ9.0AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=10.0...11.1\text{ B}; V_{MM}=15.4\text{ B}; I_{pp}=26.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TW	SMAJ10C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.1...13.6\text{ B}; V_{MM}=18.8\text{ B}; I_{pp}=21.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TX	SMAJ10AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=11.1...12.3\text{ B}; V_{MM}=17.0\text{ B}; I_{pp}=23.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TY	SMAJ11C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=12.2...14.9\text{ B}; V_{MM}=20.1\text{ B}; I_{pp}=20.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
TZ	SMAJ11AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=12.2...13.5\text{ B}; V_{MM}=18.2\text{ B}; I_{pp}=22.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
U1A	MURS105T3	ON	dr	$V_R < 50\text{ B}; I_F=1\text{ A}; V_F(I_F=1\text{ A}) < 0.71\text{ B}; I_{RR} < 35\text{ Hc}$	DO-214AA, SMB	K*A
U1B	MURS110T3	ON	dr	$V_R < 100\text{ B}; I_F=1\text{ A}; V_F(I_F=1\text{ A}) < 0.71\text{ B}; I_{RR} < 35\text{ Hc}$	DO-214AA, SMB	K*A
U1C	MURS115T3	ON	dr	$V_R < 150\text{ B}; I_F=1\text{ A}; V_F(I_F=1\text{ A}) < 0.71\text{ B}; I_{RR} < 35\text{ Hc}$	DO-214AA, SMB	K*A
U1D	MURS120T3	ON	dr	$V_R < 200\text{ B}; I_F=1\text{ A}; V_F(I_F=1\text{ A}) < 0.71\text{ B}; I_{RR} < 35\text{ Hc}$	DO-214AA, SMB	K*A
U1G	MURS140T3	ON	dr	$V_R < 400\text{ B}; I_F=1\text{ A}; V_F(I_F=1\text{ A}) < 1.05\text{ B}; I_{RR} < 75\text{ Hc}$	DO-214AA, SMB	K*A
U1J	MURS160T3	ON	dr	$V_R < 600\text{ B}; I_F=1\text{ A}; V_F(I_F=1\text{ A}) < 1.05\text{ B}; I_{RR} < 75\text{ Hc}$	DO-214AA, SMB	K*A
UA	US1A	GS	fd	$V_R=50\text{ B}; I_F=1\text{ A}; C_0=17\text{ nF}$	DO-214AC, SMA	K*A
UB	US1B	GS	fd	$V_R=100\text{ B}; I_F=1\text{ A}; C_0=17\text{ nF}$	DO-214AC, SMA	K*A
UD	SMAJ12C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=13.3...16.3\text{ B}; V_{MM}=22.0\text{ B}; I_{pp}=18.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UD	US1D	GS	fd	$V_R=200\text{ B}; I_F=1\text{ A}; C_0=17\text{ nF}$	DO-214AC, SMA	K*A
UE	SMAJ12AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=13.3...14.7\text{ B}; V_{MM}=19.9\text{ B}; I_{pp}=20.1\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UF	SMAJ13C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=14.4...17.6\text{ B}; V_{MM}=23.8\text{ B}; I_{pp}=16.8\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UG	SMAJ13AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=14.4...15.9\text{ B}; V_{MM}=21.5\text{ B}; I_{pp}=18.6\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UG	US1G	GS	fd	$V_R=400\text{ B}; I_F=1\text{ A}; C_0=17\text{ nF}$	DO-214AC, SMA	K*A
UH	SMAJ14C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=15.6...19.1\text{ B}; V_{MM}=25.8\text{ B}; I_{pp}=15.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UJ	US1J	GS	fd	$V_R=600\text{ B}; I_F=1\text{ A}; C_0=15\text{ nF}$	DO-214AC, SMA	K*A



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1-2
UK	SMAJ14AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 15.6...17.2 \text{ B}$; $V_{WM} = 23.2 \text{ B}$; $I_{PP} = 17.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UL	SMAJ15C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.7...20.4 \text{ B}$; $V_{WM} = 26.9 \text{ B}$; $I_{PP} = 14.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UM	SMAJ15AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 16.7...18.5 \text{ B}$; $V_{WM} = 24.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 16.4 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UN	SMAJ16C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.8...21.8 \text{ B}$; $V_{WM} = 28.8 \text{ B}$; $I_{PP} = 13.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UP	SMAJ16AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 17.8...19.7 \text{ B}$; $V_{WM} = 26.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 15.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UQ	SMAJ17C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 18.9...23.1 \text{ B}$; $V_{WM} = 30.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 13.1 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UR	SMAJ17AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 18.9...20.9 \text{ B}$; $V_{WM} = 27.6 \text{ B}$; $I_{PP} = 14.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
US	SMAJ18C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20.0...24.4 \text{ B}$; $V_{WM} = 32.2 \text{ B}$; $I_{PP} = 12.4 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UT	SMAJ18AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 20.0...22.1 \text{ B}$; $V_{WM} = 29.2 \text{ B}$; $I_{PP} = 13.7 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UU	SMAJ20C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.2...27.1 \text{ B}$; $V_{WM} = 35.8 \text{ B}$; $I_{PP} = 11.1 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UV	SMAJ20AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 22.2...24.5 \text{ B}$; $V_{WM} = 32.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 12.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UW	SMAJ22C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 24.4...29.8 \text{ B}$; $V_{WM} = 39.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 10.1 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UX	SMAJ22AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 24.4...26.9 \text{ B}$; $V_{WM} = 35.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 11.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UY	SMAJ24C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 26.7...32.6 \text{ B}$; $V_{WM} = 43.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 9.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
UZ	SMAJ24AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 26.7...29.5 \text{ B}$; $V_{WM} = 38.9 \text{ B}$; $I_{PP} = 10.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VD	SMAJ26C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 28.9...31.9 \text{ B}$; $V_{WM} = 46.6 \text{ B}$; $I_{PP} = 8.6 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VE	SMAJ26AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 28.9...25.3 \text{ B}$; $V_{WM} = 42.1 \text{ B}$; $I_{PP} = 9.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VF	SMAJ28C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 31.1...38.0 \text{ B}$; $V_{WM} = 50.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 8.0 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VG	SMAJ28AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 31.1...34.4 \text{ B}$; $V_{WM} = 45.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 8.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VH	SMAJ30C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 33.3...40.7 \text{ B}$; $V_{WM} = 53.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 7.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VK	SMAJ30AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 33.3...36.8 \text{ B}$; $V_{WM} = 48.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 8.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VL	SMAJ33C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 36.7...44.9 \text{ B}$; $V_{WM} = 59.0 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.8 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VM	SMAJ33AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 36.7...40.6 \text{ B}$; $V_{WM} = 53.3 \text{ B}$; $I_{PP} = 7.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VN	SMAJ36C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 40.0...48.9 \text{ B}$; $V_{WM} = 64.3 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VP	SMAJ36AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 40.0...44.2 \text{ B}$; $V_{WM} = 58.1 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.9 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VQ	SMAJ40C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 44.4...54.3 \text{ B}$; $V_{WM} = 71.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.6 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VR	SMAJ40AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 44.4...49.1 \text{ B}$; $V_{WM} = 64.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 6.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VS	SMAJ43C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 47.8...58.4 \text{ B}$; $V_{WM} = 76.7 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VT	SMAJ43AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 47.8...52.8 \text{ B}$; $V_{WM} = 69.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.7 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VU	SMAJ45C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 50.0...61.1 \text{ B}$; $V_{WM} = 80.3 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.0 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VV	SMAJ45AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 50.0...55.3 \text{ B}$; $V_{WM} = 72.7 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VW	SMAJ48C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 53.3...65.1 \text{ B}$; $V_{WM} = 85.5 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.7 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VX	SMAJ48AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 53.3...58.9 \text{ B}$; $V_{WM} = 77.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 5.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VY	SMAJ51C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 56.7...69.3 \text{ B}$; $V_{WM} = 91.1 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.4 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
VZ	SMAJ51AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 56.7...62.7 \text{ B}$; $V_{WM} = 82.4 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.9 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
WD	SMAJ54C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 60.0...73.3 \text{ B}$; $V_{WM} = 96.3 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
WE	SMAJ54AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 60.0...66.3 \text{ B}$; $V_{WM} = 87.1 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.6 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
WF	SMAJ58C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 64.4...78.7 \text{ B}$; $V_{WM} = 103 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.9 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
WG	SMAJ58AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 64.4...71.2 \text{ B}$; $V_{WM} = 93.6 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
WH	SMAJ60C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 66.7...81.5 \text{ B}$; $V_{WM} = 107 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.7 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
WK	SMAJ60AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 66.7...73.7 \text{ B}$; $V_{WM} = 96.8 \text{ B}$; $I_{PP} = 4.1 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
WL	SMAJ64C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 71.1...86.4 \text{ B}$; $V_{WM} = 114 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
WM	SMAJ64AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 71.1...78.6 \text{ B}$; $V_{WM} = 103 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.9 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
WN	SMAJ70C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 77.8...95.1 \text{ B}$; $V_{WM} = 125 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.2 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
WO	BZX284-B2V4	PHIL	dz	$V_2 (I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 2.35...2.45 \text{ B}$; $Z_{TK} < 100 \text{ Ohm}$	SOD-110	K*А
WP	BZX284-B2V7	PHIL	dz	$V_2 (I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 2.65...2.75 \text{ B}$; $Z_{TK} < 100 \text{ Ohm}$	SOD-110	K*А
WP	SMAJ70AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 77.8...86.0 \text{ B}$; $V_{WM} = 113 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.5 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
WQ	BZX284-B3V0	PHIL	dz	$V_2 (I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 2.94...3.06 \text{ B}$; $Z_{TK} < 95 \text{ Ohm}$	SOD-110	K*А
WQ	SMAJ75C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 83.3...102 \text{ B}$; $V_{WM} = 134 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.0 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
WR	BZX284-B3V3	PHIL	dz	$V_2 (I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 3.23...3.37 \text{ B}$; $Z_{TK} < 95 \text{ Ohm}$	SOD-110	K*А
WR	SMAJ75AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 83.3...92.1 \text{ B}$; $V_{WM} = 121 \text{ B}$; $I_{PP} = 3.3 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x
WS	BZX284-B3V6	PHIL	dz	$V_2 (I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 3.53...3.67 \text{ B}$; $Z_{TK} < 90 \text{ Ohm}$	SOD-110	K*А
WS	SMAJ78C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T = 1.0 \text{ mA}) = 86.7...106 \text{ B}$; $V_{WM} = 139 \text{ B}$; $I_{PP} = 2.9 \text{ A}$	DO-214AC, SMA	x*x



DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
WT	BZX284-B3V9	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=3.82...3.98\text{ B}$; $Z_{T1}<90\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
WT	SMAJ78AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=86.7...95.8\text{ B}$; $V_{MM}=126\text{ B}$; $I_{pp}=2.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
WU	BZX284-B4V3	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=4.21...4.39\text{ B}$; $Z_{T1}<90\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
WU	SMAJ85C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=94.4...115\text{ B}$; $V_{MM}=151\text{ B}$; $I_{pp}=2.6\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
WV	BZX284-B4V7	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=4.61...4.79\text{ B}$; $Z_{T1}<80\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
WV	SMAJ85AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=94.4...104\text{ B}$; $V_{MM}=137\text{ B}$; $I_{pp}=2.9\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
WW	BZX284-B5V1	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=5.0...5.2\text{ B}$; $Z_{T1}<60\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
WW	SMAJ90C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=100...122\text{ B}$; $V_{MM}=160\text{ B}$; $I_{pp}=2.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
WX	BZX284-B5V6	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=5.49...5.71\text{ B}$; $Z_{T1}<40\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
WX	SMAJ90AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=100...111\text{ B}$; $V_{MM}=146\text{ B}$; $I_{pp}=2.7\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
WY	BZX284-B6V2	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=6.08...6.32\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
WY	SMAJ100C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=111...136\text{ B}$; $V_{MM}=179\text{ B}$; $I_{pp}=2.2\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
WZ	BZX284-B6V8	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=6.66...6.94\text{ B}$; $Z_{T1}<15\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
WZ	SMAJ100AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=111...123\text{ B}$; $V_{MM}=162\text{ B}$; $I_{pp}=2.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
XA	BZX284-B7V5	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=7.35...7.65\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XB	BZX284-B8V2	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=8.04...8.36\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XC	BZX284-B9V1	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=8.92...9.28\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XD	BZX284-B10	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=9.8...10.2\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XD	SMAJ110C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=122...149\text{ B}$; $V_{MM}=196\text{ B}$; $I_{pp}=2.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
XE	BZX284-B11	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=10.8...11.2\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XE	SMAJ110AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=122...135\text{ B}$; $V_{MM}=177\text{ B}$; $I_{pp}=2.3\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
XF	BZX284-B12	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=11.8...12.2\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XF	SMAJ120C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=133...163\text{ B}$; $V_{MM}=214\text{ B}$; $I_{pp}=1.9\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
XG	BZX284-B13	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=12.7...13.3\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XG	SMAJ120AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=133...147\text{ B}$; $V_{MM}=193\text{ B}$; $I_{pp}=2.0\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
XH	BZX284-B15	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=14.7...15.3\text{ B}$; $Z_{T1}<15\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XH	SMAJ130C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=144...176\text{ B}$; $V_{MM}=231\text{ B}$; $I_{pp}=1.7\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
XI	BZX284-B16	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=15.7...16.3\text{ B}$; $Z_{T1}<20\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XJ	BZX284-B18	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=17.6...18.4\text{ B}$; $Z_{T1}<20\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XK	BZX284-B20	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=19.6...20.4\text{ B}$; $Z_{T1}<20\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XK	SMAJ130AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=144...159\text{ B}$; $V_{MM}=209\text{ B}$; $I_{pp}=1.9\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
XL	BZX284-B22	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=21.6...22.4\text{ B}$; $Z_{T1}<25\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XL	SMAJ150C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=167...204\text{ B}$; $V_{MM}=268\text{ B}$; $I_{pp}=1.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
XM	BZX284-B24	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=23.5...24.5\text{ B}$; $Z_{T1}<30\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XM	SMAJ150AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=167...185\text{ B}$; $V_{MM}=243\text{ B}$; $I_{pp}=1.6\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
XN	BZX284-B27	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=26.5...27.5\text{ B}$; $Z_{T1}<40\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XN	SMAJ160C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=178...218\text{ B}$; $V_{MM}=287\text{ B}$; $I_{pp}=1.4\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
XO	BZX284-B30	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=29.4...30.6\text{ B}$; $Z_{T1}<40\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XP	BZX284-B33	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=32.3...33.7\text{ B}$; $Z_{T1}<40\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XP	SMAJ160AC	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=178...197\text{ B}$; $V_{MM}=259\text{ B}$; $I_{pp}=1.5\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
XQ	BZX284-B36	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=35.3...36.7\text{ B}$; $Z_{T1}<60\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XQ	SMAJ170C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=189...231\text{ B}$; $V_{MM}=304\text{ B}$; $I_{pp}=1.3\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
XR	BZX284-B39	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=38.2...39.8\text{ B}$; $Z_{T1}<75\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XR	SMAJ170C	VISH	vs	$V_{BR}(I_T=1.0\text{ mA})=189...209\text{ B}$; $V_{MM}=275\text{ B}$; $I_{pp}=1.4\text{ A}$	DO-214AC, SMA	К*Х
XS	BZX284-B43	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=42.1...43.9\text{ B}$; $Z_{T1}<80\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XT	BZX284-B47	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=46.1...47.9\text{ B}$; $Z_{T1}<90\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XU	BZX284-B51	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=50.0...52.0\text{ B}$; $Z_{T1}<110\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XV	BZX284-B56	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=54.9...57.1\text{ B}$; $Z_{T1}<120\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XW	BZX284-B62	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=60.8...63.2\text{ B}$; $Z_{T1}<140\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XX	BZX284-B68	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=66.6...69.4\text{ B}$; $Z_{T1}<160\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
XY	BZX284-B75	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=73.5...76.5\text{ B}$; $Z_{T1}<175\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
YO	BZX284-C2V4	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=2.2...2.8\text{ B}$; $Z_{T1}<100\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
YP	BZX284-C2V7	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=2.5...2.9\text{ B}$; $Z_{T1}<100\text{ Ом}$	SOD-110	К*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц-1*2
YQ	BZX284-C3V0	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=2.8\text{...}3.2\text{ B}$; $Z_{T21}<95\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
YR	BZX284-C3V3	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=3.1\text{...}3.5\text{ B}$; $Z_{T21}<95\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
YS	BZX284-C3V6	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=3.4\text{...}3.8\text{ B}$; $Z_{T21}<90\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
YT	BZX284-C3V9	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=3.7\text{...}4.1\text{ B}$; $Z_{T21}<90\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
YU	BZX284-C4V3	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=4\text{...}4.6\text{ B}$; $Z_{T21}<90\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
YV	BZX284-C4V7	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=4.4\text{...}5\text{ B}$; $Z_{T21}<80\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
YW	BZX284-C5V1	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=4.8\text{...}5.4\text{ B}$; $Z_{T21}<60\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
YX	BZX284-C5V6	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=5.2\text{...}6\text{ B}$; $Z_{T21}<40\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
YY	BZX284-C6V2	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=5.8\text{...}6.6\text{ B}$; $Z_{T21}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
YZ	BZX284-C6V8	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=6.4\text{...}7.2\text{ B}$; $Z_{T21}<15\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
Z100	UZ2100	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=3\text{ mA})=90\text{...}110\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=3\text{ mA})<300\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z12	UZ212	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=10\text{ mA})=10.8\text{...}13.2\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=10\text{ mA})<30\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z13	UZ213	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=10\text{ mA})=11.7\text{...}14.3\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=10\text{ mA})<30\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z15	UZ215	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=10\text{ mA})=13.5\text{...}16.5\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=10\text{ mA})<30\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z16	UZ216	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=10\text{ mA})=14.4\text{...}17.6\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=10\text{ mA})<30\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z18	UZ218	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=10\text{ mA})=16.2\text{...}19.8\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=10\text{ mA})<30\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z20	UZ220	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=10\text{ mA})=18.0\text{...}22.0\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=10\text{ mA})<30\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z22	UZ222	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=10\text{ mA})=19.8\text{...}24.2\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=10\text{ mA})<30\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z24	UZ224	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=10\text{ mA})=21.6\text{...}26.4\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=10\text{ mA})<30\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z27	UZ227	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=10\text{ mA})=24.3\text{...}29.7\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=10\text{ mA})<30\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z30	UZ230	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=10\text{ mA})=27.0\text{...}33.0\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=10\text{ mA})<30\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z33	UZ233	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=10\text{ mA})=29.7\text{...}36.3\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=10\text{ mA})<30\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z36	UZ236	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=9\text{ mA})=32.4\text{...}39.6\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=9\text{ mA})<30\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z43	UZ243	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=7\text{ mA})=38.7\text{...}47.3\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=7\text{ mA})<40\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z47	UZ247	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=6\text{ mA})=42.3\text{...}51.7\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=6\text{ mA})<65\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z51	UZ251	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=6\text{ mA})=45.9\text{...}56.1\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=6\text{ mA})<65\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z68	UZ268	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=4\text{ mA})=61.2\text{...}74.8\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=4\text{ mA})<120\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z75	UZ275	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=4\text{ mA})=67.5\text{...}82.5\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=4\text{ mA})<150\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
Z82	UZ282	TOSH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=3\text{ mA})=73.8\text{...}90.2\text{ B}$; $Z_{T21}(I_{zT2}=3\text{ mA})<170\text{ Ом}$	DO-214AA, SMB	К*А
ZA	BZX284-C7V5	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=7\text{...}7.9\text{ B}$; $Z_{T21}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
ZB	BZX284-C8V2	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=7.7\text{...}8.7\text{ B}$; $Z_{T21}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
ZC	BZX284-C9V1	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=8.5\text{...}9.6\text{ B}$; $Z_{T21}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
ZD	BZX284-C10	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=9.4\text{...}10.6\text{ B}$; $Z_{T21}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
ZE	BZX284-C11	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=10.4\text{...}11.6\text{ B}$; $Z_{T21}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
ZF	BZX284-C12	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=11.4\text{...}12.7\text{ B}$; $Z_{T21}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
ZG	BZX284-C13	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=12.4\text{...}14.1\text{ B}$; $Z_{T21}<10\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
ZH	BZX284-C15	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=13.8\text{...}15.6\text{ B}$; $Z_{T21}<15\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
ZHK	SM225V1	STM	dz	$V_{z2}=5.1\text{ B}$; $P_S=2\text{ Вт}$	DO-214AC, SMA	К*А
ZHK	SMA25V1	VISH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=100\text{ mA})=4.8\text{...}5.4\text{ B}$; $Z_{T21}=5.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
ZHL	SM225V6	STM	dz	$V_{z2}=5.6\text{ B}$; $P_S=2\text{ Вт}$	DO-214AC, SMA	К*А
ZHL	SMA25V6	VISH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=100\text{ mA})=5.2\text{...}6.0\text{ B}$; $Z_{T21}=2.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
ZHN	SMA26V2	VISH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=100\text{ mA})=5.8\text{...}6.6\text{ B}$; $Z_{T21}=2.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
ZHO	SMA26V8	VISH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=100\text{ mA})=6.4\text{...}7.21\text{ B}$; $Z_{T21}=2.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
ZHO	SMA27V5	VISH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=100\text{ mA})=7.0\text{...}7.9\text{ B}$; $Z_{T21}=2.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
ZHR	SMA28V2	VISH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=100\text{ mA})=7.7\text{...}8.7\text{ B}$; $Z_{T21}=2.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
ZHT	SMA29V1	VISH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=50\text{ mA})=8.5\text{...}9.6\text{ B}$; $Z_{T21}=4.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
ZHU	SMA210	VISH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=50\text{ mA})=9.4\text{...}10.6\text{ B}$; $Z_{T21}=4.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
ZHW	SM2212	STM	dz	$V_{z2}=12.0\text{ B}$; $P_S=2\text{ Вт}$	DO-214AC, SMA	К*А
ZHW	SMA212	VISH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=50\text{ mA})=11.4\text{...}12.7\text{ B}$; $Z_{T21}=7.0\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
ZHZ	SMA215	VISH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=50\text{ mA})=13.8\text{...}15.6\text{ B}$; $Z_{T21}=10\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А
ZI	BZX284-C16	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=15.3\text{...}17.1\text{ B}$; $Z_{T21}<20\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
ZJ	BZX284-C18	PHIL	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=5\text{ mA})=16.8\text{...}19.1\text{ B}$; $Z_{T21}<20\text{ Ом}$	SOD-110	К*А
ZJA	SMA216	VISH	dz	$V_{z2}(I_{zT2}=25\text{ mA})=15.3\text{...}17.1\text{ B}$; $Z_{T21}=15\text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	К*А



DO214, SMA, SMB, SMC, SOD110

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
ZJF	SMZ218	STM	dz	$V_2 = 18.0 \text{ В}; P_5 = 2 \text{ Вт}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZJF	SMAZ18	VISH	dz	$V_2 (I_2 = 25 \text{ mA}) = 16.8...19.1 \text{ В}; Z_{2T} = 15 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZJG	SMAZ20	VISH	dz	$V_2 (I_2 = 25 \text{ mA}) = 18.8...21.2 \text{ В}; Z_{2T} = 15 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZJK	SMAZ22	VISH	dz	$V_2 (I_2 = 25 \text{ mA}) = 20.8...23.3 \text{ В}; Z_{2T} = 15 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZJL	SMAZ24	VISH	dz	$V_2 (I_2 = 25 \text{ mA}) = 22.8...25.6 \text{ В}; Z_{2T} = 15 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZJN	SMAZ27	VISH	dz	$V_2 (I_2 = 25 \text{ mA}) = 25.1...28.9 \text{ В}; Z_{2T} = 15 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZJQ	SMZ230	STM	dz	$V_2 = 30.0 \text{ В}; P_5 = 2 \text{ Вт}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZJQ	SMAZ30	VISH	dz	$V_2 (I_2 = 25 \text{ mA}) = 28...32 \text{ В}; Z_{2T} = 15 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZJR	SMAZ33	VISH	dz	$V_2 (I_2 = 25 \text{ mA}) = 31...35 \text{ В}; Z_{2T} = 15 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZJS	SMAZ36	VISH	dz	$V_2 (I_2 = 10 \text{ mA}) = 34...38 \text{ В}; Z_{2T} = 40 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZJT	SMAZ39	VISH	dz	$V_2 (I_2 = 10 \text{ mA}) = 37...41 \text{ В}; Z_{2T} = 40 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZJV	SMAZ47	VISH	dz	$V_2 (I_2 = 10 \text{ mA}) = 44...50 \text{ В}; Z_{2T} = 45 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZK	BZX284-C20	PHIL	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ mA}) = 18.8...21.2 \text{ В}; Z_{2T} < 20 \text{ Ом}$	SOD-110	K*А
ZKM	SMAZ68	VISH	dz	$V_2 (I_2 = 10 \text{ mA}) = 64...72 \text{ В}; Z_{2T} = 80 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZKQ	SMAZ100	VISH	dz	$V_2 (I_2 = 5.0 \text{ mA}) = 94...106 \text{ В}; Z_{2T} = 200 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZKR	SMZ2150	STM	dz	$V_2 = 150 \text{ В}; P_5 = 2 \text{ Вт}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZKR	SMAZ150	VISH	dz	$V_2 (I_2 = 5.0 \text{ mA}) = 138...156 \text{ В}; Z_{2T} = 300 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZKW	SMAZ200	VISH	dz	$V_2 (I_2 = 5.0 \text{ mA}) = 188...212 \text{ В}; Z_{2T} = 350 \text{ Ом}$	DO-214AC, SMA	K*А
ZL	BZX284-C22	PHIL	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ mA}) = 21.6...22.4 \text{ В}; Z_{2T} < 25 \text{ Ом}$	SOD-110	K*А
ZLGP	TPSMB20A	GS	vs	$V_{BR} (I_T = 1.0 \text{ mA}) = 19.0...21.0 \text{ В}; V_{WM} = 17.1 \text{ В}; I_{pp} = 21.7 \text{ А}$	DO-214AA, SMB	K*А
ZM	BZX284-C24	PHIL	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ mA}) = 22.8...23.3 \text{ В}; Z_{2T} < 30 \text{ Ом}$	SOD-110	K*А
ZN	BZX284-C27	PHIL	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ mA}) = 25.1...28.9 \text{ В}; Z_{2T} < 40 \text{ Ом}$	SOD-110	K*А
ZO	BZX284-C30	PHIL	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ mA}) = 28...32 \text{ В}; Z_{2T} < 40 \text{ Ом}$	SOD-110	K*А
ZP	BZX284-C33	PHIL	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ mA}) = 31...35 \text{ В}; Z_{2T} < 40 \text{ Ом}$	SOD-110	K*А
ZQ	BZX284-C36	PHIL	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ mA}) = 34...38 \text{ В}; Z_{2T} < 60 \text{ Ом}$	SOD-110	K*А
ZR	BZX284-C39	PHIL	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ mA}) = 37...41 \text{ В}; Z_{2T} < 75 \text{ Ом}$	SOD-110	K*А
ZS	BZX284-C43	PHIL	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ mA}) = 40...46 \text{ В}; Z_{2T} < 80 \text{ Ом}$	SOD-110	K*А
ZT	BZX284-C47	PHIL	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ mA}) = 44...50 \text{ В}; Z_{2T} < 90 \text{ Ом}$	SOD-110	K*А
ZU	BZX284-C51	PHIL	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ mA}) = 48...54 \text{ В}; Z_{2T} < 110 \text{ Ом}$	SOD-110	K*А
ZV	BZX284-C56	PHIL	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ mA}) = 52...60 \text{ В}; Z_{2T} < 120 \text{ Ом}$	SOD-110	K*А
ZW	BZX284-C62	PHIL	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ mA}) = 58...66 \text{ В}; Z_{2T} < 140 \text{ Ом}$	SOD-110	K*А
ZX	BZX284-C68	PHIL	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ mA}) = 64...72 \text{ В}; Z_{2T} < 160 \text{ Ом}$	SOD-110	K*А
ZY	BZX284-C75	PHIL	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ mA}) = 70...79 \text{ В}; Z_{2T} < 175 \text{ Ом}$	SOD-110	K*А



SOD123/323, DO215/216

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
40	ZL1S400	ZETEX	shd	$V_R < 40\text{ В}; I_R < 0.52\text{ А}; V_F (I_F = 0.4\text{ А}) < 0.5\text{ В}; I_S < 10\text{ мкА}; C_D < 15\text{ пФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
46	BAT46J	STM	shd	$V_R < 100\text{ В}; I_F < 150\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 0.45\text{ мВ}; C_D < 10\text{ пФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
86	BAT54J	STM	shd	$V_R < 30\text{ В}; I_R < 300\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 0.9\text{ В}; I_S < 1\text{ мкА}; C_D < 10\text{ пФ}; t_{BR} < 5\text{ нс}$	SOD-323, SC-76	К*А
0 2	GDZ2V0B	VISH	dz	$V_Z = 2.0\text{ В}; Z_{T1} (I_Z = 5\text{ мА}) = 100\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
1 (кра)	BB669	INF	var	$V_R < 30\text{ В}; I_R < 20\text{ мА}; I_S < 0.01\text{ мкА}; C_{1B} = 51...31.5\text{ нФ}; C_{2B} = 2.5...2.9$	SOD-323, SC-76	К*А
1 2	GDZ2V2B	VISH	dz	$V_Z = 2.2\text{ В}; Z_{T1} (I_Z = 5\text{ мА}) = 100\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
1B	MA2J111	PAN	di	$V_R < 80\text{ В}; I_R < 100\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 1.2\text{ В}; t_{BR} < 3\text{ нс}$	SOD-323, SC-76	К*А
1C	MA2J112	PAN	di	$V_R < 40\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 200\text{ мА}) < 1.1\text{ В}; t_{BR} < 10\text{ нс}$	SOD-323, SC-76	К*А
1D	MA2J113	PAN	di	$V_R < 80\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 200\text{ мА}) < 1.1\text{ В}; t_{BR} < 10\text{ нс}$	SOD-323, SC-76	К*А
1E	MA2J114	PAN	dr	$V_R < 150\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 200\text{ мА}) < 1.2\text{ В}$	SOD-323, SC-76	К*А
1F	MA2J115	PAN	dr	$V_R < 200\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 200\text{ мА}) < 1.2\text{ В}$	SOD-323, SC-76	К*А
1H	MA2J116	PAN	di	$V_R < 40\text{ В}; I_R < 100\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 1.2\text{ В}; t_{BR} < 100\text{ нс}$	SOD-323, SC-76	К*А
1P	CMDZ18L	CSI	dz	$V_Z (I_{Z1} = 0.5\text{ мА}) = 18\text{ В}; P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
2	BB419	SIEM	var	$V_R < 28\text{ В}; I_R < 20\text{ мА}; I_S < 0.02\text{ мкА}; C_{1B} = 26...32\text{ пФ}; C_{2B} / C_{25B} = 5...6.5$	SOD-123	К*А
2 (бен)	BB439	INF	var	$V_R < 28\text{ В}; I_R (V_R = 28\text{ В}) < 0.02\text{ мкА}; C_{2B} = 31.5...37.5\text{ пФ}; C_{25B} = 4.3...6\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
2 (снв)	BAR64-03W	INF	pin	$V_R < 150\text{ В}; I_R < 100\text{ мА}; V_F (I_F = 50\text{ мА}) < 1.1\text{ В}; C_D < 0.35\text{ пФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
2 2	GDZ2V4B	VISH	dz	$V_Z = 2.4\text{ В}; Z_{T1} (I_Z = 5\text{ мА}) = 100\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
20B	1PMT5920B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 60.5\text{ мА}) = 6.2\text{ В}; Z_{T1} = 2.0\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
21B	1PMT5921B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 55.1\text{ мА}) = 6.8\text{ В}; Z_{T1} = 2.5\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
22B	1PMT5922B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 50.0\text{ мА}) = 7.5\text{ В}; Z_{T1} = 3.0\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
23B	1PMT5923B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 45.7\text{ мА}) = 8.2\text{ В}; Z_{T1} = 3.5\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
24B	1PMT5924B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 41.2\text{ мА}) = 9.1\text{ В}; Z_{T1} = 4.0\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
25B	1PMT5925B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 37.5\text{ мА}) = 10\text{ В}; Z_{T1} = 4.5\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
27B	1PMT5927B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 31.2\text{ мА}) = 12\text{ В}; Z_{T1} = 6.5\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
29B	1PMT5929B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 25.0\text{ мА}) = 15\text{ В}; Z_{T1} = 9.0\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
2P	CMDZ20L	CSI	dz	$V_Z (I_{Z1} = 0.5\text{ мА}) = 20\text{ В}; P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
3 (бен)	BAT60A	INF	shd	$V_R < 10\text{ В}; I_R < 3\text{ А}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 0.15\text{ В}; I_S < 2.6\text{ мА}; C_D = 20\text{ пФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
3 2	GDZ2V7B	VISH	dz	$V_Z = 2.7\text{ В}; Z_{T1} (I_Z = 5\text{ мА}) = 110\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
30B	1PMT5930B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 23.4\text{ мА}) = 16\text{ В}; Z_{T1} = 10\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
31B	1PMT5931B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 20.8\text{ мА}) = 18\text{ В}; Z_{T1} = 12\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
33B	1PMT5933B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 17.0\text{ мА}) = 22\text{ В}; Z_{T1} = 17.5\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
34B	1PMT5934B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 15.6\text{ мА}) = 24\text{ В}; Z_{T1} = 19\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
35B	1PMT5935B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 13.9\text{ мА}) = 27\text{ В}; Z_{T1} = 23\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
36B	1PMT5936B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 12.5\text{ мА}) = 30\text{ В}; Z_{T1} = 28\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
39B	1PMT5939B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 9.6\text{ мА}) = 39\text{ В}; Z_{T1} = 45\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
3P	CMDZ22L	CSI	dz	$V_Z (I_{Z1} = 0.5\text{ мА}) = 22\text{ В}; P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
4 (бен)	BAS140W	INF	shd	$V_R < 40\text{ В}; I_R < 120\text{ мА}; V_F (I_F = 40\text{ мА}) < 1\text{ В}; I_S < 1.0\text{ мкА}; C_D < 5\text{ пФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
4 (кра)	BB644	INF	var	$V_R < 30\text{ В}; I_R < 20\text{ мА}; I_S < 0.01\text{ мкА}; C_{1B} = 39...44.5\text{ нФ}; C_{2B} = 2.4...2.75$	SOD-323, SC-76	К*А
4 2	GDZ3V0B	VISH	dz	$V_Z = 3.0\text{ В}; Z_{T1} (I_Z = 5\text{ мА}) = 120\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
41B	1PMT5941B	ON	dz	$V_Z (I_{Z1} = 8.0\text{ мА}) = 47\text{ В}; Z_{T1} = 67\text{ Ом}$	DO-216AA, PWRM	К*А
4K	MMSD3000T1	MOT	di	$V_R < 30\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 0.95\text{ В}; C_D < 2\text{ пФ}; t_{BR} < 3\text{ нс}$	SOD-123	К*А
4P	CMDZ24L	CSI	dz	$V_Z (I_{Z1} = 0.5\text{ мА}) = 24\text{ В}; P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
5 (бен)	BBY53-03W	INF	var	$V_R < 6\text{ В}; I_R < 20\text{ мА}; I_S < 0.01\text{ мкА}; C_{1B} = 4.8...5.8\text{ нФ}; C_{3B} = 1.85...3.1\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
5 (кра)	BBY57-03W	INF	var	$V_R < 10\text{ В}; I_R < 20\text{ мА}; I_S < 0.001\text{ мкА}; C_{1B} = 16.5...18.6\text{ нФ}; C_{4B} = 4...5.5\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
5 (снв)	BAT60B	INF	shd	$V_R < 10\text{ В}; I_R < 3\text{ А}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) = 0.24\text{ В}; I_S = 10\text{ мкА}; C_D = 25\text{ пФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
5 2	GDZ3V3B	VISH	dz	$V_Z = 3.3\text{ В}; Z_{T1} (I_Z = 5\text{ мА}) = 1210\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
5D	MMSD914T1	ON	di	$V_R < 100\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 1\text{ В}; C_D < 4\text{ нФ}$	SOD-123	К*А
5I	MMSD4146T1	ON	di	$V_R < 100\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 1\text{ В}; C_D < 4\text{ нФ}$	SOD-123	К*А



DO215, SOD123/323



DO216AA

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц1*2
5P	CMDZ27L	CSI	dz	$V_2(I_{ZT1} = 0.5 \text{ mA}) = 27 \text{ B}$; $P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
6 (кра)	BBY56-03W	INF	var	$V_B < 10 \text{ B}$; $I_B < 20 \text{ мА}$; $I_B < 0.005 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 37 \dots 43 \text{ нФ}$; $C_{4B} = 12.1 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
6 2	GDZ3V6B	VISH	dz	$V_2 = 3.6 \text{ B}$; $Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ mA}) = 100 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
6P	CMDZ30L	CSI	dz	$V_2(I_{ZT1} = 0.5 \text{ mA}) = 30 \text{ B}$; $P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
6S	MMSD71RK1	ON	di	$V_B < 80 \text{ B}$; $I_B < 200 \text{ мА}$; $V_F(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.2 \text{ B}$; $C_D < 2 \text{ нФ}$	SOD-123	К*А
7 (бен)	BAS170W	INF	shd	$V_B < 70 \text{ B}$; $I_B < 70 \text{ мА}$; $V_F(I_F = 15 \text{ мА}) < 1.0 \text{ B}$; $I_B < 0.1 \text{ мкА}$; $C_D < 2.0 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
7 (бен)	BBY55-03W	INF	var	$V_B < 16 \text{ B}$; $I_B < 20 \text{ мА}$; $I_B < 0.003 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 17.5 \dots 19.6 \text{ нФ}$; $C_{10B} = 5.5 \dots 6.5 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
7 2	GDZ3V9B	VISH	dz	$V_2 = 3.9 \text{ B}$; $Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ mA}) = 100 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
76	BAS70J	STM	shd	$V_B < 70 \text{ B}$; $I_B < 70 \text{ мА}$; $V_F(I_F = 1 \text{ mA}) < 0.41 \text{ B}$; $I_B < 0.1 \text{ мкА}$; $C_D < 2.0 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
7N	CMDZ1L8	CSI	dz	$V_2(I_{ZT1} = 0.5 \text{ mA}) = 1.8 \text{ B}$; $P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
7P	CMDZ33L	CSI	dz	$V_2(I_{ZT1} = 0.5 \text{ mA}) = 33 \text{ B}$; $P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
8 (жен)	BBY58-03W	INF	var	$V_B < 10 \text{ B}$; $I_B < 20 \text{ мА}$; $I_B < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 17.5 \dots 19.3 \text{ нФ}$; $C_{4B} = 5.5 \dots 6.6 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
8 2	GDZ4V3B	VISH	dz	$V_2 = 4.3 \text{ B}$; $Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ mA}) = 100 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
8N	CMDZ2L0	CSI	dz	$V_2(I_{ZT1} = 0.5 \text{ mA}) = 2.0 \text{ B}$; $P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
8P	CMDZ36L	CSI	dz	$V_2(I_{ZT1} = 0.5 \text{ mA}) = 36 \text{ B}$; $P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
9 2	GDZ4V7B	VISH	dz	$V_2 = 4.7 \text{ B}$; $Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ mA}) = 100 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
913B	1PMT5913BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 113.6 \text{ mA}) = 3.3 \text{ B}$; $Z_{T1} = 10.0 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
914B	1PMT5914BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 104.2 \text{ mA}) = 3.6 \text{ B}$; $Z_{T1} = 9.0 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
915B	1PMT5915BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 96.1 \text{ mA}) = 3.9 \text{ B}$; $Z_{T1} = 7.5 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
916B	1PMT5916BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 87.2 \text{ mA}) = 4.3 \text{ B}$; $Z_{T1} = 6.0 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
917B	1PMT5917BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 79.8 \text{ mA}) = 4.7 \text{ B}$; $Z_{T1} = 5.0 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
918B	1PMT5918BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 73.5 \text{ mA}) = 5.1 \text{ B}$; $Z_{T1} = 4.0 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
919B	1PMT5919BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 66.9 \text{ mA}) = 5.6 \text{ B}$; $Z_{T1} = 2.0 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
920B	1PMT5920BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 60.5 \text{ mA}) = 6.2 \text{ B}$; $Z_{T1} = 2.0 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
921B	1PMT5921BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 55.1 \text{ mA}) = 6.8 \text{ B}$; $Z_{T1} = 2.5 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
922B	1PMT5922BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 50.0 \text{ mA}) = 7.5 \text{ B}$; $Z_{T1} = 3.0 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
923B	1PMT5923BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 45.7 \text{ mA}) = 8.2 \text{ B}$; $Z_{T1} = 3.5 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
924B	1PMT5924BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 41.2 \text{ mA}) = 9.1 \text{ B}$; $Z_{T1} = 4.0 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
925B	1PMT5925BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 37.5 \text{ mA}) = 10 \text{ B}$; $Z_{T1} = 4.5 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
926B	1PMT5926BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 34.1 \text{ mA}) = 11 \text{ B}$; $Z_{T1} = 5.0 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
927B	1PMT5927BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 31.2 \text{ mA}) = 12 \text{ B}$; $Z_{T1} = 6.5 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
928B	1PMT5928BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 28.8 \text{ mA}) = 13 \text{ B}$; $Z_{T1} = 7.0 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
929B	1PMT5929BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 25.0 \text{ mA}) = 15 \text{ B}$; $Z_{T1} = 9.0 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
930B	1PMT5930BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 23.4 \text{ mA}) = 16 \text{ B}$; $Z_{T1} = 10 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
931B	1PMT5931BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 20.8 \text{ mA}) = 18 \text{ B}$; $Z_{T1} = 12 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
932B	1PMT5932BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 18.7 \text{ mA}) = 20 \text{ B}$; $Z_{T1} = 14 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
933B	1PMT5933BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 17.0 \text{ mA}) = 22 \text{ B}$; $Z_{T1} = 17.5 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
934B	1PMT5934BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 15.6 \text{ mA}) = 24 \text{ B}$; $Z_{T1} = 19 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
935B	1PMT5935BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 13.9 \text{ mA}) = 27 \text{ B}$; $Z_{T1} = 23 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
936B	1PMT5936BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 12.5 \text{ mA}) = 30 \text{ B}$; $Z_{T1} = 26 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
937B	1PMT5937BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 11.4 \text{ mA}) = 33 \text{ B}$; $Z_{T1} = 33 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
938B	1PMT5938BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 10.4 \text{ mA}) = 36 \text{ B}$; $Z_{T1} = 38 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
939B	1PMT5939BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 9.6 \text{ mA}) = 39 \text{ B}$; $Z_{T1} = 45 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
940B	1PMT5940BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 8.7 \text{ mA}) = 43 \text{ B}$; $Z_{T1} = 53 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
941B	1PMT5941BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 8.0 \text{ mA}) = 47 \text{ B}$; $Z_{T1} = 67 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
942B	1PMT5942BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 7.3 \text{ mA}) = 51 \text{ B}$; $Z_{T1} = 70 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
943B	1PMT5943BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 6.7 \text{ mA}) = 56 \text{ B}$; $Z_{T1} = 86 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
944B	1PMT5944BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 6.0 \text{ mA}) = 62 \text{ B}$; $Z_{T1} = 100 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
945B	1PMT5945BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 5.5 \text{ mA}) = 68 \text{ B}$; $Z_{T1} = 120 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
946B	1PMT5946BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 5.0 \text{ mA}) = 75 \text{ B}$; $Z_{T1} = 140 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
947B	1PMT5947BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 4.6 \text{ mA}) = 82 \text{ B}$; $Z_{T1} = 160 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А
948B	1PMT5948BT3	MOT	dz	$V_2(I_{ZT1} = 4.1 \text{ mA}) = 91 \text{ B}$; $Z_{T1} = 200 \text{ Ом}$	DO-216AA, PWFRM	К*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
9N	CMD22L2	CSI	dz	$V_{Z}(I_{ZT}=0.5\text{ mA})=2.2\text{ B}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
9P	CMD239L	CSI	dz	$V_{Z}(I_{ZT}=0.5\text{ mA})=39\text{ B}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
A	1S5355	ROHM	di	$V_F < 80\text{ B}$; $I_F < 225\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA}) < 1.2\text{ B}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$; $t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOD-323, SC-76	К*А
A	BAT14098	SIEM	shd	$V_F < 4\text{ B}$; $I_F < 90\text{ mA}$; $V_F(I_F=10\text{ mA}) < 0.55\text{ B}$; $C_0 < 0.35\text{ пФ}$	SOD-123	К*А
A	BA597	INF	pin	$V_F > 50\text{ B}$; $I_F < 100\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA})=0.9\text{ B}$; $I_S < 0.02\text{ мкА}$	SOD-323, SC-76	К*А
A1	MMS210T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=9.5...10.5\text{ B}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
A2	1N4148W	VIS	sd	$V_F < 75\text{ B}$; $I_F=150\text{ mA}$; $P_D=400\text{ мВт}$; $t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOD-123	К*А
A2	BA592	PHIL	dtv	$V_F < 35\text{ B}$; $I_F < 10\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA}) < 1.0\text{ B}$; $I_S < 0.02\text{ мкА}$	SOD-323, SC-76	К*А
A2	BB208-03	PHIL	var	$V_F > 10\text{ B}$; $I_F(I_F=10\text{ B}) < 0.01\text{ мкА}$; $C_{1B}=19.9...23.2\text{ пФ}$; $C_{2B}=4.5...5.4\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
A2	MMS211T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=10.45...11.55\text{ B}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
A3	1N4448W	VIS	sd	$V_F < 75\text{ B}$; $I_F=150\text{ mA}$; $P_D=500\text{ мВт}$; $t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOD-123	К*А
A3	BAP64-03	PHIL	pin	$V_F > 175\text{ B}$; $I_F < 100\text{ mA}$; $V_F(I_F=50\text{ mA}) < 1.1\text{ B}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-323, SC-76	К*А
A3	MMS212T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=11.4...12.6\text{ B}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
A4	1N4150W	VIS	sd	$V_F < 50\text{ B}$; $I_F=400\text{ mA}$; $P_D=410\text{ мВт}$; $t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOD-123	К*А
A4	1N4150W	WTE	sd	$V_F < 50\text{ B}$; $I_F=400\text{ mA}$; $P_D=410\text{ мВт}$; $t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOD-123	К*А
A4	MMS213T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=12.35...13.65\text{ B}$; $I_S < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
A5	1N4151W	VIS	sd	$V_F < 75\text{ B}$; $I_F=500\text{ mA}$; $P_D=410\text{ мВт}$; $t_{RR} < 2\text{ нс}$	SOD-123	К*А
A5	1N4151W	WTE	sd	$V_F < 75\text{ B}$; $I_F=500\text{ mA}$; $P_D=500\text{ мВт}$; $t_{RR} < 2\text{ нс}$	SOD-123	К*А
A5	BAP51-03	PHIL	pin	$V_F > 50\text{ B}$; $I_F < 50\text{ mA}$; $V_F(I_F=50\text{ mA}) < 1.1\text{ B}$; $I_S < 1\text{ мкА}$	SOD-323, SC-76	К*А
A5	MMS215T1	ON	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ mA})=14.25...15.75\text{ B}$; $I_S < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
A6	BAS16D	GS	di	$V_F < 75\text{ B}$; $I_F < 250\text{ mA}$; $V_F(I_F=150\text{ mA}) < 1.25\text{ B}$; $I_S < 50\text{ мкА}$; $C_0 < 2\text{ нФ}$; $t_{RR} < 6\text{ нс}$	SOD-123	К*А
A6	BAS16D	VISH	di	$V_F < 75\text{ B}$; $I_F < 250\text{ mA}$; $V_F(I_F=150\text{ mA}) < 1.25\text{ B}$; $I_S < 50\text{ мкА}$; $C_0 < 2\text{ нФ}$; $t_{RR} < 6\text{ нс}$	SOD-123	К*А
A6	BAS16WS	GS	di	$V_F < 75\text{ B}$; $I_F < 250\text{ mA}$; $V_F(I_F=150\text{ mA}) < 1.25\text{ B}$; $I_S < 50\text{ мкА}$; $C_0 < 2\text{ нФ}$; $t_{RR} < 6\text{ нс}$	SOD-323, SC-76	К*А
A6	BAS316	PHIL	fd	$V_F < 85\text{ B}$; $I_F < 250\text{ mA}$; $V_F(I_F=50\text{ mA}) < 1.0\text{ B}$; $C_0 < 1.5\text{ нФ}$; $t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOD-323, SC-76	К*А
A8	BAP50-03	PHIL	pin	$V_F > 50\text{ B}$; $I_F < 50\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA}) < 1.1\text{ B}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-323, SC-76	К*А
A8	BAV19W	VISH	di	$V_F < 100\text{ B}$; $I_F < 250\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA}) < 1\text{ B}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$; $C_0=1.5\text{ нФ}$; $t_{RR} < 50\text{ нс}$	SOD-123	К*А
A8	BAV19W	DIODS	di	$V_F < 100\text{ B}$; $I_F < 250\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA}) < 1\text{ B}$; $C_0 < 5\text{ нФ}$; $t_{RR} < 50\text{ нс}$	SOD-123	К*А
A8	BAV19W	WTE	di	$V_F < 100\text{ B}$; $I_F < 400\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA}) < 1\text{ B}$; $C_0 < 5\text{ нФ}$; $t_{RR} < 50\text{ нс}$	SOD-123	К*А
A8	BAV19W	TSC	di	$V_F < 100\text{ B}$; $I_F < 400\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA}) < 1\text{ B}$; $C_0 < 5\text{ нФ}$; $t_{RR} < 50\text{ нс}$	SOD-123	К*А
A8	BAV19W	MCC	di	$V_F < 100\text{ B}$; $I_F < 400\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA}) < 1\text{ B}$; $C_0 < 5\text{ нФ}$; $t_{RR} < 50\text{ нс}$	SOD-123	К*А
A80	BAV20W	WTE	di	$V_F < 150\text{ B}$; $I_F < 400\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA}) < 1\text{ B}$; $C_0 < 5\text{ нФ}$; $t_{RR} < 50\text{ нс}$	SOD-123	К*А
A82	BAV21W	WTE	di	$V_F < 200\text{ B}$; $I_F < 400\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA}) < 1\text{ B}$; $C_0 < 5\text{ нФ}$; $t_{RR} < 50\text{ нс}$	SOD-123	К*А
A9	BAV20W	VISH	di	$V_F < 150\text{ B}$; $I_F < 250\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA}) < 1\text{ B}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$; $C_0=1.5\text{ нФ}$; $t_{RR} < 50\text{ нс}$	SOD-123	К*А
AA	BAV21W	VISH	di	$V_F < 200\text{ B}$; $I_F < 250\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA}) < 1\text{ B}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$; $C_0=1.5\text{ нФ}$; $t_{RR} < 50\text{ нс}$	SOD-123	К*А
AA	ZMV829A	ZETEX	var	$V_F < 25\text{ B}$; $I_F < 200\text{ mA}$; $I_S < 0.02\text{ мкА}$; $C_{2B}=7.38...9.02\text{ нФ}$; $C_{2B}/C_{20B}=4.3...5.8$	SOD-323, SC-76	К*А
AB	ZMV830A	ZETEX	var	$V_F < 25\text{ B}$; $I_F < 200\text{ mA}$; $I_S < 0.02\text{ мкА}$; $C_{2B}=9...11\text{ нФ}$; $C_{2B}/C_{20B}=4.5...6.0$	SOD-323, SC-76	К*А
AC	ZMV831A	ZETEX	var	$V_F < 25\text{ B}$; $I_F < 200\text{ mA}$; $I_S < 0.02\text{ мкА}$; $C_{2B}=13.5...16.5\text{ нФ}$; $C_{2B}/C_{20B}=4.5...6.0$	SOD-323, SC-76	К*А
AD	ZMV832A	ZETEX	var	$V_F < 25\text{ B}$; $I_F < 200\text{ mA}$; $I_S < 0.02\text{ мкА}$; $C_{2B}=19.8...24.2\text{ нФ}$; $C_{2B}/C_{20B}=5...6.5$	SOD-323, SC-76	К*А
AE	ZMV833A	ZETEX	var	$V_F < 25\text{ B}$; $I_F < 200\text{ mA}$; $I_S < 0.02\text{ мкА}$; $C_{2B}=29.7...36.3\text{ нФ}$; $C_{2B}/C_{20B}=5...6.5$	SOD-323, SC-76	К*А
AF	ZMV834A	ZETEX	var	$V_F < 25\text{ B}$; $I_F < 200\text{ mA}$; $I_S < 0.02\text{ мкА}$; $C_{2B}=42.3...51.7\text{ нФ}$; $C_{2B}/C_{20B}=5...6.5$	SOD-323, SC-76	К*А
AG	ZMV835A	ZETEX	var	$V_F < 25\text{ B}$; $I_F < 200\text{ mA}$; $I_S < 0.02\text{ мкА}$; $C_{2B}=61.2...74.8\text{ нФ}$; $C_{2B}/C_{20B}=5...6.5$	SOD-323, SC-76	К*А
AH	ZMV930	ZETEX	var	$V_F < 12\text{ B}$; $I_F < 100\text{ mA}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$; $C_{2.5B}=4.3...5.5\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
AJ	ZMV931	ZETEX	var	$V_F < 12\text{ B}$; $I_F < 100\text{ mA}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$; $C_{2.5B}=6.5...7.8\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
AK	ZMV932	ZETEX	var	$V_F < 12\text{ B}$; $I_F < 100\text{ mA}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$; $C_{2.5B}=8.5...10.5\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
AL	ZMV933	ZETEX	var	$V_F < 12\text{ B}$; $I_F < 100\text{ mA}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$; $C_{2.5B}=18...27\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
AM	ZMV933A	ZETEX	var	$V_F < 12\text{ B}$; $I_F < 100\text{ mA}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$; $C_{2.5B}=20.25...24.75\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
AN	ZMV934	ZETEX	var	$V_F < 12\text{ B}$; $I_F < 100\text{ mA}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$; $C_{2.5B}=40...65\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
AO	ZMV934A	ZETEX	var	$V_F < 12\text{ B}$; $I_F < 100\text{ mA}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$; $C_{2.5B}=47.25...57.75\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
AP	CMD22L4	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}=0.5\text{ mA})=2.4\text{ B}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
AR	CMD243L	CSI	dz	$V_Z(I_{ZT}=0.5\text{ mA})=43\text{ B}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
B	BAS16-03W	INF	di	$V_F < 80\text{ B}$; $I_F < 250\text{ mA}$; $V_F(I_F=150\text{ mA}) < 1.25\text{ B}$; $I_S < 50\text{ мкА}$	SOD-323, SC-76	К*А
B	BAT15098	SIEM	shd	$V_F < 4\text{ B}$; $I_F < 110\text{ mA}$; $V_F(I_F=10\text{ mA}) < 0.32\text{ B}$; $C_0 < 0.35\text{ пФ}$	SOD-123	К*А



DO215, SOD123/323



DO216AA

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц1*2
B0	BZX399C4V3	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=4.09...4.52 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
B1	BZX399C1V8	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=1.715...1.89 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
B2	BZX399C2V0	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=1.9...2.1 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
B3	BZX399C2V2	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=2.09...2.31 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
B4	BZX399C2V4	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=2.28...2.52 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
B5	BZX399C2V7	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=2.57...2.84 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
B6	BZX399C3V0	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=2.85...3.15 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
B7	BZX399C3V3	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=3.14...3.47 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
B8	BZX399C3V6	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=3.42...3.78 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
B9	BZX399C3V9	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=3.71...4.1 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
BA	BZX399C4V7	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=4.47...4.94 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
BB	BZX399C5V1	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=4.85...5.36 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
BC	BZX399C5V6	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=5.32...5.88 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
BD	BZX399C6V2	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=5.89...6.51 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
BD	ZHCS400	ZETEX	shd	$V_R < 40 \text{ В}; I_R < 400 \text{ мА}; V_F(I_F=400 \text{ мА}) < 0.5 \text{ В}; I_R < 40 \text{ мА}; C_D=20 \text{ пФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
BE	BZX399C6V8	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=6.46...7.14 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
BF	BZX399C7V5	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=7.13...7.88 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
BG	BZX399C8V2	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=7.79...8.61 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
BH	BZX399C9V1	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=8.65...9.56 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
BJ	BZX399C10	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=9.5...10.5 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
BK	BZX399C11	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=10.45...11.55 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
BL	BZX399C12	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=11.4...12.6 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
BM	BZX399C13	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=12.35...13.65 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
BN	BZX399C15	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=14.25...15.75 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
BP	BZX399C16	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=15.2...16.8 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
BP	CMXDZL5	CSI	dz	$V_2(I_{T1}=0.5 \text{ мА})=2.5 \text{ В}; P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
BQ	BZX399C18	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=17.1...18.9 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
BR	BZX399C20	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=19...21 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
BR	CMXDZ47L	CSI	dz	$V_2(I_{T1}=0.5 \text{ мА})=47 \text{ В}; P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
BS	BZX399C22	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=20.9...23.1 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
BT	BZX399C24	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=22.8...25.2 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
BU	BZX399C27	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=25.65...28.35 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
BV	BZX399C30	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=28.5...31.5 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
BW	BZX399C33	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=31.35...34.65 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
BX	BZX399C36	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=34.2...37.8 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
BY	BZX399C39	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=37.05...40.95 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
BZ	BZX399C43	PHIL	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мА})=40.85...45.15 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
C	KV1832E	TOKO	var	$C=4...17 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
C (6en)	BAT165	INF	shd	$V_R < 40 \text{ В}; I_F < 750 \text{ мА}; V_F(I_F=750 \text{ мА}) < 0.7 \text{ В}; C_D < 12 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
C (6en)	BAT65	SIEM	shd	$V_R < 30 \text{ В}; I_F < 500 \text{ мА}; V_F(I_F=250 \text{ мА}) < 0.7 \text{ В}; I_R < 10 \text{ мА}; C_D < 12 \text{ нФ}$	SOD-123	К*А
C1	1SS352	TOSH	di	$V_R < 80 \text{ В}; I_F < 200 \text{ мА}; V_F(I_F=100 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}; I_R < 0.5 \text{ мА}$	SOD-323, SC-76	К*А
C1	MMSZ52218T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА})=2.28...2.52 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOD-123	К*А
C2	MMSZ52228T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА})=2.37...2.63 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOD-123	К*А
C3	MMSZ52238T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА})=2.57...2.84 \text{ В}; I_R < 75 \text{ мА}$	SOD-123	К*А
C4	MMSZ52248T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА})=2.66...2.94 \text{ В}; I_R < 75 \text{ мА}$	SOD-123	К*А
C48	CMHD4448	CNTRL	di	$V_R < 30 \text{ В}; I_F < 500 \text{ мА}; V_F(I_F=10 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_D < 4 \text{ нФ}; t_{RR} < 4 \text{ нс}$	SOD-123	К*А
C5	MMSZ5225	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА})=3 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}$	SOD-123	К*А
C5	MMSZ52258T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА})=2.85...3.15 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}$	SOD-123	К*А
CA	MMSZ4691	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=5.89...6.51 \text{ В}; I_R < 10 \text{ мА}$	SOD-123	К*А
CA	MMSZ4691T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА})=5.89...6.51 \text{ В}; I_R < 10 \text{ мА}$	SOD-123	К*А
CA	ZMV829B	ZETEX	var	$V_R < 25 \text{ В}; I_F < 200 \text{ мА}; I_R < 0.02 \text{ мА}; C_{2B}=7.79...8.61 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{20B}=4.3...5.8$	SOD-323, SC-76	К*А
CB	ZMV830B	ZETEX	var	$V_R < 25 \text{ В}; I_F < 200 \text{ мА}; I_R < 0.02 \text{ мА}; C_{2B}=9.5...10.5 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{20B}=4.5...6.0$	SOD-323, SC-76	К*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
CC	MMSZ4678T1	ON	dz	$V_Z (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 1.71 \dots 1.89 \text{ В}; I_{R1} < 7.5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CC	ZMV831B	ZETEX	var	$V_R < 25 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; I_{R1} < 0.02 \text{ мкА}; C_{2B} = 14.25 \dots 15.75 \text{ пФ}; C_{2B}/C_{20B} = 4.5 \dots 6.0$	SOD-323, SC-76	К*А
CC1	CMHZ5221B	CSI	dz	$V_Z = 2.4 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CC2	CMHZ5222B	CSI	dz	$V_Z = 2.5 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CC3	CMHZ5223B	CSI	dz	$V_Z = 2.7 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CC4	CMHZ5224B	CSI	dz	$V_Z = 2.8 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CC5	CMHZ5225B	CSI	dz	$V_Z = 3.0 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CD	MMSZ4679T1	ON	dz	$V_Z (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 1.90 \dots 2.10 \text{ В}; I_{R1} < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CD	ZMV832B	ZETEX	var	$V_R < 25 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; I_{R1} < 0.02 \text{ мкА}; C_{2B} = 20.9 \dots 23.1 \text{ пФ}; C_{2B}/C_{20B} = 5 \dots 6.5$	SOD-323, SC-76	К*А
CD1	CMHZ5226B	CSI	dz	$V_Z = 3.3 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CD2	CMHZ5227B	CSI	dz	$V_Z = 3.6 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CD3	CMHZ5228B	CSI	dz	$V_Z = 3.9 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CD4	CMHZ5229B	CSI	dz	$V_Z = 4.3 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CD5	CMHZ5230B	CSI	dz	$V_Z = 4.7 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CE	MMSZ4680T1	ON	dz	$V_Z (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 2.09 \dots 2.31 \text{ В}; I_{R1} < 4 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CE	ZMV833B	ZETEX	var	$V_R < 25 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; I_{R1} < 0.02 \text{ мкА}; C_{2B} = 31.35 \dots 34.65 \text{ пФ}; C_{2B}/C_{20B} = 5 \dots 6.5$	SOD-323, SC-76	К*А
CE1	CMHZ5231B	CSI	dz	$V_Z = 5.1 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CE2	CMHZ5232B	CSI	dz	$V_Z = 5.6 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CE3	CMHZ5233B	CSI	dz	$V_Z = 6.0 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CE4	CMHZ5234B	CSI	dz	$V_Z = 6.2 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CE5	CMHZ5235B	CSI	dz	$V_Z = 6.8 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CF	MMSZ4681	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 2.28 \dots 2.52 \text{ В}; I_{R1} < 2 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CF	MMSZ4681T1	ON	dz	$V_Z (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 2.28 \dots 2.52 \text{ В}; I_{R1} < 2 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CF	ZMV834B	ZETEX	var	$V_R < 25 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; I_{R1} < 0.02 \text{ мкА}; C_{2B} = 44.65 \dots 49.35 \text{ пФ}; C_{2B}/C_{20B} = 5 \dots 6.5$	SOD-323, SC-76	К*А
CF1	CMHZ5236B	CSI	dz	$V_Z = 7.5 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CF2	CMHZ5237B	CSI	dz	$V_Z = 8.2 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CF3	CMHZ5238B	CSI	dz	$V_Z = 8.7 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CF4	CMHZ5239B	CSI	dz	$V_Z = 9.1 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CF5	CMHZ5240B	CSI	dz	$V_Z = 10 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CG	ZMV835B	ZETEX	var	$V_R < 25 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; I_{R1} < 0.02 \text{ мкА}; C_{2B} = 64.6 \dots 71.4 \text{ пФ}; C_{2B}/C_{20B} = 5 \dots 6.5$	SOD-323, SC-76	К*А
CH	MMSZ4682	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 2.57 \dots 2.84 \text{ В}; I_{R1} < 1 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CH	MMSZ4682T1	ON	dz	$V_Z (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 2.57 \dots 2.84 \text{ В}; I_{R1} < 1 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CH1	CMHZ5241B	CSI	dz	$V_Z = 11 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CH2	CMHZ5242B	CSI	dz	$V_Z = 12 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CH3	CMHZ5243B	CSI	dz	$V_Z = 13 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CH4	CMHZ5244B	CSI	dz	$V_Z = 14 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CH5	CMHZ5245B	CSI	dz	$V_Z = 15 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CJ	MMSZ4683	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 2.85 \dots 3.15 \text{ В}; I_{R1} < 0.8 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CJ	MMSZ4683T1	ON	dz	$V_Z (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 2.85 \dots 3.15 \text{ В}; I_{R1} < 0.8 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CJ1	CMHZ5246B	CSI	dz	$V_Z = 16 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CJ2	CMHZ5247B	CSI	dz	$V_Z = 17 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CJ3	CMHZ5248B	CSI	dz	$V_Z = 18 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CJ4	CMHZ5249B	CSI	dz	$V_Z = 19 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CJ5	CMHZ5250B	CSI	dz	$V_Z = 20 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CK	MMSZ4684	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 3.14 \dots 3.47 \text{ В}; I_{R1} < 7.5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CK	MMSZ4684T1	ON	dz	$V_Z (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 3.14 \dots 3.47 \text{ В}; I_{R1} < 7.5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CK1	CMHZ5251B	CSI	dz	$V_Z = 22 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CK2	CMHZ5252B	CSI	dz	$V_Z = 24 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CK3	CMHZ5253B	CSI	dz	$V_Z = 25 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CK4	CMHZ5254B	CSI	dz	$V_Z = 27 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CK5	CMHZ5255B	CSI	dz	$V_Z = 28 \text{ В} (5\%); P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CL1	MMSZ2V4ET1	ON	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 2.28 \dots 2.52 \text{ В}; I_{R1} < 50 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А



DO215, SOD123/323



DO216AA

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц1*2
CL2	MMSZ2V7ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 2.57...2.84\text{ B}$; $I_H < 20\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CL3	MMSZ3V0ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 2.85...3.15\text{ B}$; $I_H < 10\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CL4	MMSZ3V3ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 3.14...3.47\text{ B}$; $I_H < 5\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CL5	MMSZ3V6ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 3.42...3.78\text{ B}$; $I_H < 5\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CL6	MMSZ3V9ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 3.71...4.10\text{ B}$; $I_H < 3\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CL7	MMSZ4V3ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 4.09...4.52\text{ B}$; $I_H < 3\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CL8	MMSZ4V7ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 4.47...4.94\text{ B}$; $I_H < 2\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CL9	MMSZ5V1ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 4.85...5.36\text{ B}$; $I_H < 1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CM	MMSZ4685	VISH	dz	$V_2(I_{T2}=50\text{ мкА}) = 3.42...3.78\text{ B}$; $I_H < 7.5\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CM	MMSZ4685T1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=50\text{ мкА}) = 3.42...3.78\text{ B}$; $I_H < 7.5\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CM1	CMHZ5256B	CSI	dz	$V_2 = 30\text{ B (5\%)}$; $P_D < 500\text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CM1	MMSZ5V6ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 5.32...5.88\text{ B}$; $I_H < 3\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CM2	CMHZ5257B	CSI	dz	$V_2 = 33\text{ B (5\%)}$; $P_D < 500\text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CM2	MMSZ6V2ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 5.89...6.51\text{ B}$; $I_H < 2\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CM3	CMHZ5258B	CSI	dz	$V_2 = 36\text{ B (5\%)}$; $P_D < 500\text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CM3	MMSZ6V8ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 6.46...7.14\text{ B}$; $I_H < 1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CM4	CMHZ5259B	CSI	dz	$V_2 = 39\text{ B (5\%)}$; $P_D < 500\text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CM4	MMSZ7V5ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 7.13...7.88\text{ B}$; $I_H < 0.7\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CM5	CMHZ5260B	CSI	dz	$V_2 = 43\text{ B (5\%)}$; $P_D < 500\text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CM5	MMSZ8V2ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 7.79...8.61\text{ B}$; $I_H < 0.5\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CM6	MMSZ9V1ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 8.65...9.56\text{ B}$; $I_H < 0.2\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CM7	MMSZ10ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 9.5...10.5\text{ B}$; $I_H < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CM8	MMSZ11ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 10.45...11.55\text{ B}$; $I_H < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CM9	MMSZ12ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 11.4...12.6\text{ B}$; $I_H < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CN	MMSZ4686	VISH	dz	$V_2(I_{T2}=50\text{ мкА}) = 3.71...4.10\text{ B}$; $I_H < 5\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CN	MMSZ4686T1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=50\text{ мкА}) = 3.71...4.10\text{ B}$; $I_H < 5\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CN1	CMHZ5261B	CSI	dz	$V_2 = 47\text{ B (5\%)}$; $P_D < 500\text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CN1	MMSZ13ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 12.35...13.65\text{ B}$; $I_H < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CN2	CMHZ5262B	CSI	dz	$V_2 = 51\text{ B (5\%)}$; $P_D < 500\text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CN2	MMSZ15ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 14.25...15.75\text{ B}$; $I_H < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CN3	CMHZ5263B	CSI	dz	$V_2 = 56\text{ B (5\%)}$; $P_D < 500\text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CN3	MMSZ16ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 15.2...16.8\text{ B}$; $I_H < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CN4	CMHZ5264B	CSI	dz	$V_2 = 60\text{ B (5\%)}$; $P_D < 500\text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CN4	MMSZ18ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 17.1...18.9\text{ B}$; $I_H < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CN5	CMHZ5265B	CSI	dz	$V_2 = 62\text{ B (5\%)}$; $P_D < 500\text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CN5	MMSZ20ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 19.0...21.0\text{ B}$; $I_H < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CN6	MMSZ22ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 20.9...23.1\text{ B}$; $I_H < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CN7	MMSZ24ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 22.8...25.2\text{ B}$; $I_H < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CN8	MMSZ27ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 25.65...28.35\text{ B}$; $I_H < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CN9	MMSZ30ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 28.50...31.5\text{ B}$; $I_H < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CO3	CMHD2003	CNTRL	di	$V_A < 250\text{ B}$; $I_C < 250\text{ mA}$; $V_F(I_F = 100\text{ mA}) < 1\text{ B}$; $C_D = 1.5\text{ нФ}$; $t_{\text{рег}} < 50\text{ нс}$	SOD-123	К*А
CP	CMDZ2L7	CSI	dz	$V_2(I_{T2} = 0.5\text{ mA}) = 2.7\text{ B}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
CP	MMSZ4687	VISH	dz	$V_2(I_{T2}=50\text{ мкА}) = 4.09...4.52\text{ B}$; $I_H < 4\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CP	MMSZ4687T1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=50\text{ мкА}) = 4.09...4.52\text{ B}$; $I_H < 4\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CP1	CMHZ5266B	CSI	dz	$V_2 = 68\text{ B (5\%)}$; $P_D < 500\text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CP1	MMSZ33ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 31.35...34.65\text{ B}$; $I_H < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CP2	CMHZ5267B	CSI	dz	$V_2 = 75\text{ B (5\%)}$; $P_D < 500\text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CP2	MMSZ36ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 34.2...37.8\text{ B}$; $I_H < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CP3	CMHZ5268B	CSI	dz	$V_2 = 82\text{ B (5\%)}$; $P_D < 500\text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CP3	MMSZ39ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 37.05...41.0\text{ B}$; $I_H < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
CP4	CMHZ5269B	CSI	dz	$V_2 = 87\text{ B (5\%)}$; $P_D < 500\text{ мВт}$	SOD-123	К*А
CP4	MMSZ43ET1	ON	dz	$V_2(I_{T2}=5\text{ mA}) = 40.85...45.15\text{ B}$; $I_H < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1•2
CP5	CMHZ5270B	CSI	dz	$V_2 = 91 \text{ B (5\%); } P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К•А
CP5	MMSZ47E1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 44.65...49.35 \text{ B; } I_R < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
CP6	MMSZ51E1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 48.45...53.55 \text{ B; } I_R < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
CP7	MMSZ56E1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 53.20...58.80 \text{ B; } I_R < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
CR1	CMHZ5271B	CSI	dz	$V_2 = 100 \text{ B (5\%); } P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К•А
CR2	CMHZ5272B	CSI	dz	$V_2 = 110 \text{ B (5\%); } P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К•А
CR3	CMHZ5273B	CSI	dz	$V_2 = 120 \text{ B (5\%); } P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К•А
CR4	CMHZ5274B	CSI	dz	$V_2 = 130 \text{ B (5\%); } P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К•А
CR5	CMHZ5275B	CSI	dz	$V_2 = 140 \text{ B (5\%); } P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К•А
CS1	CMHZ5276B	CSI	dz	$V_2 = 150 \text{ B (5\%); } P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К•А
CS2	CMHZ5277B	CSI	dz	$V_2 = 160 \text{ B (5\%); } P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К•А
CS3	CMHZ5278B	CSI	dz	$V_2 = 170 \text{ B (5\%); } P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К•А
CS4	CMHZ5279B	CSI	dz	$V_2 = 180 \text{ B (5\%); } P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К•А
C55	CMHZ5280B	CSI	dz	$V_2 = 190 \text{ B (5\%); } P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К•А
CT	MMSZ4688	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 4.47...4.94 \text{ B; } I_R < 10 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
CT	MMSZ4688T1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 4.47...4.94 \text{ B; } I_R < 10 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
CT1	CMHZ5281B	CSI	dz	$V_2 = 200 \text{ B (5\%); } P_D < 500 \text{ мВт}$	SOD-123	К•А
CU	MMSZ4689	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 4.85...5.36 \text{ B; } I_R < 10 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
CU	MMSZ4689T1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 4.85...5.36 \text{ B; } I_R < 10 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
CV	MMSZ4690	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 5.32...5.88 \text{ B; } I_R < 10 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
CV	MMSZ4690T1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 5.32...5.88 \text{ B; } I_R < 10 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
CX	MMSZ4692	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 6.46...7.14 \text{ B; } I_R < 10 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
CX	MMSZ4692T1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 6.46...7.14 \text{ B; } I_R < 10 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
CY	MMSZ4693	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 7.13...7.88 \text{ B; } I_R < 10 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
CY	MMSZ4693T1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 7.13...7.88 \text{ B; } I_R < 10 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
CZ	MMSZ4694	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 7.79...8.61 \text{ B; } I_R < 1 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
CZ	MMSZ4694T1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 7.79...8.61 \text{ B; } I_R < 1 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
D	1SS376	ROHM	di	$V_R < 250 \text{ B; } I_F < 300 \text{ mA; } V_F (I_F = 100 \text{ mA}) < 1.2 \text{ B; } t_{RR} < 100 \text{ нс}$	SOD-323, SC-76	К•А
D	BAS21-03W	INF	inf	$V_R < 200 \text{ B; } I_F < 250 \text{ mA; } V_F (I_F = 100 \text{ mA}) < 1.0 \text{ B; } I_R < 0.1 \text{ мкА}$	SOD-323, SC-76	К•А
D1	MMSZ5226	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 20 \text{ mA}) = 3.3 \text{ B; } I_R < 25 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
D1	MMSZ5226B1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 20 \text{ mA}) = 3.14...3.47 \text{ B; } I_R < 25 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
D2	MMSZ5227	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 20 \text{ mA}) = 3.6 \text{ B; } I_R < 15 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
D2	MMSZ5227B1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 20 \text{ mA}) = 3.42...3.78 \text{ B; } I_R < 15 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
D3	MMSZ5228	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 20 \text{ mA}) = 3.9 \text{ B; } I_R < 10 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
D3	MMSZ5228B1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 20 \text{ mA}) = 3.71...4.10 \text{ B; } I_R < 10 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
D4	MMSZ5229	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 20 \text{ mA}) = 4.3 \text{ B; } I_R < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
D4	MMSZ5229B1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 20 \text{ mA}) = 4.09...4.52 \text{ B; } I_R < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
D5	MMSZ5230	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 20 \text{ mA}) = 4.7 \text{ B; } I_R < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
D5	MMSZ5230B1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 20 \text{ mA}) = 4.47...4.94 \text{ B; } I_R < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
D76	BAR18J	SGS	shd	$V_{BR} > 70 \text{ B; } V_F (I_F = 1 \text{ mA}) < 0.41 \text{ B; } I_R < 200 \text{ mA; } C_T < 1.7 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К•А
DA	MMSZ4708	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 20.9...23.1 \text{ B; } I_R < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
DA	MMSZ4708T1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 20.9...23.1 \text{ B; } I_R < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
DC	MMSZ4695	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 8.27...9.14 \text{ B; } I_R < 1 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
DC	MMSZ4695T1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 8.27...9.14 \text{ B; } I_R < 1 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
DD	MMSZ4696	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 8.65...9.56 \text{ B; } I_R < 1 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
DD	MMSZ4696T1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 8.65...9.56 \text{ B; } I_R < 1 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
DE	MMSZ4697	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 9.5...10.5 \text{ B; } I_R < 1 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
DE	MMSZ4697T1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 9.5...10.5 \text{ B; } I_R < 1 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
DF	MMSZ4698	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 10.5...11.6 \text{ B; } I_R < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
DF	MMSZ4698T1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 10.5...11.6 \text{ B; } I_R < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
DH	MMSZ4699	VISH	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 11.4...12.6 \text{ B; } I_R < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А
DH	MMSZ4699T1	ON	dz	$V_2 (I_{ZT} = 50 \text{ мкА}) = 11.4...12.6 \text{ B; } I_R < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К•А



DO215, SOD123/323



DO216AA

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
DJ	MMSZ4700	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 12.4...13.7 \text{ В}; I_{T1} < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DJ	MMSZ4700T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 12.4...13.7 \text{ В}; I_{T1} < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DK	MMSZ4701	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 13.3...14.7 \text{ В}; I_{T1} < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DK	MMSZ4701T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 13.3...14.7 \text{ В}; I_{T1} < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DM	MMSZ4702	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 14.3...15.8 \text{ В}; I_{T1} < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DM	MMSZ4702T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 14.3...15.8 \text{ В}; I_{T1} < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DN	MMSZ4703	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 15.2...16.8 \text{ В}; I_{T1} < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DN	MMSZ4703T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 15.2...16.8 \text{ В}; I_{T1} < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DP	CMCZ2L8	CSI	dz	$V_2(I_{T1}=0.5 \text{ мА}) = 2.8 \text{ В}; P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
DP	MMSZ4704	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 16.2...17.9 \text{ В}; I_{T1} < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DP	MMSZ4704T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 16.2...17.9 \text{ В}; I_{T1} < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DT	MMSZ4705	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 17.1...18.9 \text{ В}; I_{T1} < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DT	MMSZ4705T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 17.1...18.9 \text{ В}; I_{T1} < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DU	MMSZ4706	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 18.1...20.0 \text{ В}; I_{T1} < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DU	MMSZ4706T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 18.1...20.0 \text{ В}; I_{T1} < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DV	MMSZ4707	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 19.0...21.0 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DV	MMSZ4707T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 19.0...21.0 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DY	MMSZ4710	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 23.8...26.3 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DY	MMSZ4710T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 23.8...26.3 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DZ	MMSZ4709	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 22.8...25.2 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
DZ	MMSZ4709T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 22.8...25.2 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
E	1SS380	ROHM	di	$V_R < 40 \text{ В}; I_F < 225 \text{ мА}; V_F(I_F=100 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}; I_S < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-323, SC-76	К*А
E1	MMSZ5231	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА}) = 5.1 \text{ В}; I_S < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
E1	MMSZ5231BT1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА}) = 4.85...5.36 \text{ В}; I_S < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
E2	MMSZ5232	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА}) = 5.6 \text{ В}; I_S < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
E2	MMSZ5232BT1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА}) = 5.32...5.88 \text{ В}; I_S < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
E3	MMSZ5233	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА}) = 6.0 \text{ В}; I_S < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
E3	MMSZ5233BT1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА}) = 5.70...6.30 \text{ В}; I_S < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
E4	MMSZ5234	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА}) = 6.2 \text{ В}; I_S < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
E4	MMSZ5234BT1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА}) = 5.89...6.51 \text{ В}; I_S < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
E5	MMSZ5235	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА}) = 6.8 \text{ В}; I_S < 3 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
E5	MMSZ5235BT1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА}) = 6.46...7.14 \text{ В}; I_S < 3 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
EA	MMSZ4711	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 25.7...28.4 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
EA	MMSZ4711T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 25.7...28.4 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
EC	MMSZ4712	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 26.6...29.4 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
EC	MMSZ4712T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 26.6...29.4 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
ED	MMSZ4713	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 28.5...31.5 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
ED	MMSZ4713T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 28.5...31.5 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
EE	MMSZ4714	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 31.4...34.7 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
EE	MMSZ4714T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 31.4...34.7 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
EF	MMSZ4715	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 34.2...37.8 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
EF	MMSZ4715T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 34.2...37.8 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
EH	MMSZ4716	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 37.1...41.0 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
EH	MMSZ4716T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 37.05...40.95 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
EJ	MMSZ4717	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 40.9...45.2 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
EJ	MMSZ4717T1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=50 \text{ мкА}) = 40.85...45.15 \text{ В}; I_{T1} < 0.01 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
F	KV1831E	TOKO	var	$C = 2.5...22 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
F1	MMSZ5236	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА}) = 7.5 \text{ В}; I_S < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
F1	MMSZ5236BT1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА}) = 7.13...7.88 \text{ В}; I_S < 3 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
F2	MMSZ5237	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА}) = 8.2 \text{ В}; I_S < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
F2	MMSZ5237BT1	ON	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА}) = 7.79...8.61 \text{ В}; I_S < 3 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
F3	MMSZ5238	VISH	dz	$V_2(I_{T1}=20 \text{ мА}) = 8.7 \text{ В}; I_S < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
F3	MMS25238BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=20\text{ mA})=8.27\dots9.14\text{ B}$; $I_2 < 3\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
F4	MMS25239	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=20\text{ mA})=9.1\text{ B}$; $I_2 < 5\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
F4	MMS25239BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=20\text{ mA})=8.65\dots9.56\text{ B}$; $I_2 < 3\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
F5	1SS403	TOSH	di	$V_R < 200\text{ B}$; $I_F < 300\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA}) < 1.2\text{ B}$; $I_2 < 1\text{ мкА}$; $t_{\text{RR}} < 60\text{ нс}$	SOD-323, SC-76	К*А
F5	MMS25240	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=20\text{ mA})=10\text{ B}$; $I_2 < 3\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
F5	MMS25240BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=20\text{ mA})=9.5\dots10.5\text{ B}$; $I_2 < 3\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
FP	CMD23L3	CSI	dz	$V_2(I_{ZT}=0.5\text{ mA})=3.3\text{ B}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
G	BAR63-03W	INF	pin	$V_R < 50\text{ B}$; $I_C < 100\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA}) < 1.2\text{ B}$; $I_2 < 0.01\text{ мкА}$	SOD-323, SC-76	К*А
G	KV1181E	TOKO	var	$C=2\dots16\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
GP	CMD23L6	CSI	dz	$V_2(I_{ZT}=0.5\text{ mA})=3.6\text{ B}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
H	BBY51-03W	INF	var	$V_R < 7\text{ B}$; $I_C < 10\text{ mA}$; $I_2 < 0.01\text{ мкА}$; $C_{1B}=5.05\dots5.75\text{ нФ}$; $C_{4V}=2.5\dots3.7\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
H1	MMS25241	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=20\text{ mA})=11\text{ B}$; $I_2 < 3\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
H1	MMS25241BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=20\text{ mA})=10.45\dots11.55\text{ B}$; $I_2 < 2\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
H2	MMS25242	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=20\text{ mA})=12\text{ B}$; $I_2 < 3\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
H2	MMS25242BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=20\text{ mA})=11.4\dots12.6\text{ B}$; $I_2 < 1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
H3	MMS25243	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=9.5\text{ mA})=13\text{ B}$; $I_2 < 0.5\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
H3	MMS25243BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=9.5\text{ mA})=12.35\dots13.65\text{ B}$; $I_2 < 0.5\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
H4	MMS25244	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=8.5\text{ mA})=14\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
H4	MMS25244BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=8.5\text{ mA})=13.30\dots14.70\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
H5	MMS25245	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=8.5\text{ mA})=15\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
H5	MMS25245BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=8.5\text{ mA})=14.25\dots15.75\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
HP	CMD23L9	CSI	dz	$V_2(I_{ZT}=0.5\text{ mA})=3.9\text{ B}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
I(Gen)	BBY52-03W	INF	var	$V_R < 7\text{ B}$; $I_C < 10\text{ mA}$; $I_2 < 0.01\text{ мкА}$; $C_{1B}=1.4\dots2.2\text{ нФ}$; $C_{4B}=0.85\dots1.45\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
J1	MMS25246	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=7.8\text{ mA})=16\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
J1	MMS25246BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=7.8\text{ mA})=15.2\dots16.8\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
J2	MMS25247	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=7.4\text{ mA})=17\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
J2	MMS25247BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=7.0\text{ mA})=16.15\dots17.85\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
J3	MMS25248	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=7.0\text{ mA})=18\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
J3	MMS25248BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=7.0\text{ mA})=17.1\dots18.9\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
J4	MMS25249	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=6.6\text{ mA})=19\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
J5	MMS25250	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=6.2\text{ mA})=20\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
J5	MMS25250BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=6.2\text{ mA})=19.0\dots21.0\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
JP	CMD24L3	CSI	dz	$V_2(I_{ZT}=0.5\text{ mA})=4.3\text{ B}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
K	BAT68-03W	INF	shd	$V_R < 8\text{ B}$; $I_C < 130\text{ mA}$; $V_F(I_F=10\text{ mA}) < 0.5\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$; $C_D < 1.0\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
K1	MMS25251	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5.6\text{ mA})=22\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
K1	MMS25251BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=5.6\text{ mA})=20.9\dots23.1\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
K2	MMS25252	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5.2\text{ mA})=24\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
K2	MMS25252BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=5.2\text{ mA})=22.8\dots25.2\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
K3	MMS25253	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5.0\text{ mA})=25\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
K3	MMS25253BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=5.0\text{ mA})=23.75\dots26.25\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
K4	MMS25254	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=4.6\text{ mA})=27\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
K4	MMS25254BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=5.0\text{ mA})=25.65\dots28.35\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
K5	MMS25255	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=4.5\text{ mA})=28\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
K5	MMS25255BT1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=4.5\text{ mA})=26.6\dots29.4\text{ B}$; $I_2 < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
KP	CMD24L7	CSI	dz	$V_2(I_{ZT}=0.5\text{ mA})=4.7\text{ B}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
L	BAT62-03W	INF	shd	$V_R < 40\text{ B}$; $I_C < 20\text{ mA}$; $V_F(I_F=2\text{ mA}) < 1\text{ B}$; $I_2 < 10\text{ мкА}$; $C_D < 0.6\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
L2	BAT42W	WTE	shd	$V_R < 30\text{ B}$; $I_C < 200\text{ mA}$; $V_F(I_F=50\text{ mA}) < 0.65\text{ мВ}$; $C_D=10\text{ нФ}$	SOD-123	К*А
L2	BAT42W	VISH	shd	$V_R < 30\text{ B}$; $I_C < 200\text{ mA}$; $V_F(I_F=50\text{ mA}) < 0.65\text{ мВ}$; $C_D=10\text{ нФ}$	SOD-123	К*А
L2	BAT42WS	WTE	shd	$V_R < 30\text{ B}$; $I_C < 200\text{ mA}$; $V_F(I_F=50\text{ mA}) < 0.65\text{ мВ}$; $C_D=10\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
L2	BAT42WS	PANJIT	shd	$V_R < 30\text{ B}$; $I_C < 200\text{ mA}$; $V_F(I_F=10\text{ mA}) < 0.4\text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
L3	BAT43W	WTE	shd	$V_R < 30\text{ B}$; $I_C < 200\text{ mA}$; $V_F(I_F=15\text{ mA}) < 0.45\text{ мВ}$; $C_D=10\text{ нФ}$	SOD-123	К*А
L3	BAT43W	VISH	shd	$V_R < 30\text{ B}$; $I_C < 200\text{ mA}$; $V_F(I_F=15\text{ mA}) < 0.45\text{ мВ}$; $C_D=10\text{ нФ}$	SOD-123	К*А

**DO215, SOD123/323****DO216AA**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц1*2
L3	BAT43WS	WTE	shd	$V_B < 30\text{ В}; I_F < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 15\text{ мА}) < 0.45\text{ мВ}; C_0 = 10\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
L3	BAT43WS	PANJIT	shd	$V_B < 30\text{ В}; I_F < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 2\text{ мА}) < 0.33\text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
L4	BAT54WS	PANJIT	shd	$V_B < 30\text{ В}; I_F < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 1\text{ мА}) < 0.32\text{ мВ}$	SOD-323, SC-76	К*А
L6	BAT46W	VISH	shd	$V_B < 100\text{ В}; I_F < 150\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 0.45\text{ мВ}; C_0 = 10\text{ нФ}$	SOD-123	К*А
L6	BAT46W	TSC	shd	$V_B < 100\text{ В}; I_F < 150\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 0.45\text{ мВ}; C_0 = 10\text{ нФ}$	SOD-123	К*А
L7	BAT17W	VISH	shd	$V_B < 4\text{ В}; I_F < 30\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 0.6\text{ В}; I_S < 0.25\text{ мкА}; C_0 < 0.75\text{ нФ}$	SOD-123	К*А
LP	CMDZ5L1	CSI	dz	$V_2 (I_{T2} = 0.5\text{ мА}) = 5.1\text{ В}; P_0 < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
M	BB512	SIEM	var	$V_B < 12\text{ В}; I_F < 50\text{ мА}; I_S < 0.02\text{ мкА}; C_{0.5B} = 440...520\text{ нФ}; C_{1B}/C_{0.5B} > 15$	SOD-123	К*А
M (син)	BAR65-03W	INF	pin	$V_B < 30\text{ В}; I_F < 100\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; C_0 < 0.9\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
M1	MMSZ5256	VISH	dz	$V_2 (I_{T2} = 4.2\text{ мА}) = 30\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
M1	MMSZ5256BT1	ON	dz	$V_2 (I_{T2} = 4.2\text{ мА}) = 28.5...31.5\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
M2	MMSZ5257	VISH	dz	$V_2 (I_{T2} = 3.8\text{ мА}) = 33\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
M2	MMSZ5257BT1	ON	dz	$V_2 (I_{T2} = 3.8\text{ мА}) = 31.35...34.65\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
M3	MMSZ5258	VISH	dz	$V_2 (I_{T2} = 3.4\text{ мА}) = 36\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
M3	MMSZ5258BT1	ON	dz	$V_2 (I_{T2} = 3.4\text{ мА}) = 34.2...37.8\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
M4	MMSZ5259	VISH	dz	$V_2 (I_{T2} = 3.2\text{ мА}) = 39\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
M4	MMSZ5259BT1	ON	dz	$V_2 (I_{T2} = 3.2\text{ мА}) = 37.05...40.95\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
M5	MMSZ5260	VISH	dz	$V_2 (I_{T2} = 3.0\text{ мА}) = 43\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
M5	MMSZ5260BT1	ON	dz	$V_2 (I_{T2} = 3.0\text{ мА}) = 40.85...45.15\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
N1	MMSZ5261	VISH	dz	$V_2 (I_{T2} = 2.7\text{ мА}) = 47\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
N1	MMSZ5261BT1	ON	dz	$V_2 (I_{T2} = 2.7\text{ мА}) = 44.65...49.35\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
N2	MMSZ5262	VISH	dz	$V_2 (I_{T2} = 2.5\text{ мА}) = 51\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
N2	MMSZ5262BT1	ON	dz	$V_2 (I_{T2} = 2.5\text{ мА}) = 48.45...53.55\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
N3	MMSZ5263	VISH	dz	$V_2 (I_{T2} = 2.2\text{ мА}) = 56\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
N3	MMSZ5263BT1	ON	dz	$V_2 (I_{T2} = 2.2\text{ мА}) = 53.20...58.80\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
N4	MMSZ5264	VISH	dz	$V_2 (I_{T2} = 2.1\text{ мА}) = 60\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
N4	MMSZ5264BT1	ON	dz	$V_2 (I_{T2} = 2.1\text{ мА}) = 57.00...63.00\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
N5	MMSZ5265	VISH	dz	$V_2 (I_{T2} = 2.0\text{ мА}) = 62\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
N5	MMSZ5265BT1	ON	dz	$V_2 (I_{T2} = 2\text{ мА}) = 58.90...65.10\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
NP	CMDZ5L6	CSI	dz	$V_2 (I_{T2} = 0.5\text{ мА}) = 5.6\text{ В}; P_0 < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
O (6en)	BAT14-03W	SIEM	shd	$V_B < 4\text{ В}; I_F < 90\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 0.66\text{ мВ}; C_0 < 0.35\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
OP	CMDZ6L2	CSI	dz	$V_2 (I_{T2} = 0.5\text{ мА}) = 6.2\text{ В}; P_0 < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
P	BA586	INF	pin	$V_B < 50\text{ В}; I_F < 50\text{ мА}; V_F (I_F = 50\text{ мА}) < 1.15\text{ В}; I_S < 0.05\text{ мкА}; C_0 < 0.2\text{ нФ}$	SOD-123	К*А
P	KV1841E	TOKO	var	$C = 7...15\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
P (6en)	BAT15-03W	INF	shd	$V_B < 4\text{ В}; I_F < 110\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 0.41\text{ В}; C_0 < 0.35\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
P1	BB131	PHIL	var	$V_B > 30\text{ В}; I_S (V_B = 30\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{0.5B} = 8...17\text{ нФ}; C_{28B} = 0.7...1.055\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
P1	MMSZ5266	VISH	dz	$V_2 (I_{T2} = 1.8\text{ мА}) = 68\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
P1	MMSZ5266BT1	ON	dz	$V_2 (I_{T2} = 1.8\text{ мА}) = 64.60...71.40\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
P2	BB132	PHIL	var	$V_B > 30\text{ В}; I_S (V_B = 30\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{0.5B} = 60...75\text{ нФ}; C_{28B} = 2.3...2.75\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
P2	MMSZ5267	VISH	dz	$V_2 (I_{T2} = 1.7\text{ мА}) = 75\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
P2	MMSZ5267BT1	ON	dz	$V_2 (I_{T2} = 1.7\text{ мА}) = 71.25...78.75\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
P3	BB133	PHIL	var	$V_B > 30\text{ В}; I_S (V_B = 30\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{0.5B} = 38...46\text{ нФ}; C_{28B} = 2.2...2.6\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
P3	BB133	LRC	var	$V_B > 30\text{ В}; I_S (V_B = 30\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{0.5B} = 38...46\text{ нФ}; C_{28B} = 2.2...2.6\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
P3	MMSZ5268BT1	ON	dz	$V_2 (I_{T2} = 1.5\text{ мА}) = 77.9...86.1\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
P4	BB134	PHIL	var	$V_B > 30\text{ В}; I_S (V_B = 30\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{0.5B} = 17.5...21\text{ нФ}; C_{28B} = 1.7...2.1\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
P4	BB134	LRC	var	$V_B > 30\text{ В}; I_S (V_B = 30\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{0.5B} = 17.5...21\text{ нФ}; C_{28B} = 1.7...2.1\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
P4	MMSZ5269BT1	ON	dz	$V_2 (I_{T2} = 1.4\text{ мА}) = 82.65...91.35\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
P5	BB135	PHIL	var	$V_B > 30\text{ В}; I_S (V_B = 30\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{0.5B} = 17.5...21\text{ нФ}; C_{28B} = 1.7...2.1\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
P5	BB135	LRC	var	$V_B > 30\text{ В}; I_S (V_B = 30\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{0.5B} = 17.5...21\text{ нФ}; C_{28B} = 1.7...2.1\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
P5	MMSZ5270BT1	ON	dz	$V_2 (I_{T2} = 1.4\text{ мА}) = 86.45...95.55\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
P6	BB146	PHIL	var	$V_B > 30\text{ В}; I_S (V_B = 30\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{0.5B} = 35...43\text{ нФ}; C_{28B} = 1.7...2.1\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
P7	BB147	PHIL	var	$V_B > 30\text{ В}; I_S (V_B = 30\text{ В}) < 0.02\text{ мкА}; C_{0.5B} = 92...112\text{ нФ}; C_{28B} = 2.4...2.8\text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
P8	BB148	PHIL	var	$V_R > 30B$; $I_R (V_R = 30B) < 0.02 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 36.8...41.8 \text{ нФ}$; $C_{2B} = 2.4...2.75 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
P9	BB149	PHIL	var	$V_R > 30B$; $I_R (V_R = 30B) < 0.02 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 18...19.5 \text{ нФ}$; $C_{2B} = 1.9...2.25 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
PA	BB149	LRC	var	$V_R > 30B$; $I_R (V_R = 30B) < 0.02 \text{ мкА}$; $C_{0.5B} = 18...19.5 \text{ нФ}$; $C_{2B} = 1.9...2.25 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
PA	BB151	PHIL	var	$V_R > 10B$; $I_R (V_R = 10B) < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 15.4...17 \text{ нФ}$; $C_{2B} = 9.9...11.3 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
PB	BB152	PHIL	var	$V_R > 32B$; $I_R (V_R = 30B) < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 52...62 \text{ нФ}$; $C_{2B} = 2.48...2.89 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
PC	BB153	PHIL	var	$V_R > 32B$; $I_R (V_R = 30B) < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 34.65...42.35 \text{ нФ}$; $C_{2B} = 2.361...2.754 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
PE	BB155	PHIL	var	$V_R > 10B$; $I_R (V_R = 10B) < 0.01 \text{ мкА}$; $CO.34V = 45.2...49.8 \text{ нФ}$; $CO.82V = 24.55...26.7 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
PF	BB156	PHIL	var	$V_R > 10B$; $I_R (V_R = 10B) < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 14.4...17.6 \text{ нФ}$; $C_{2B} = 7.6...9.6 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
PG	BB157	PHIL	var	$V_R > 30B$; $I_R (V_R = 30B) < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 37.5...43.8 \text{ нФ}$; $C_{2B} = 2.42...2.76 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
PH	BB158	PHIL	var	$V_R > 30B$; $I_R (V_R = 30B) < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 36.8...41.8 \text{ нФ}$; $C_{2B} = 2.4...2.75 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
PJ	BB159	PHIL	var	$V_R > 30B$; $I_R (V_R = 30B) < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 18...19.5 \text{ нФ}$; $C_{2B} = 1.9...2.25 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
PK	BB164	PHIL	var	$V_R > 30B$; $I_R (V_R = 30B) < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 62...76 \text{ нФ}$; $C_{2B} = 2.9...3.4 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
PL	BB149A	PHIL	var	$V_R > 30B$; $I_R (V_R = 30B) < 0.02 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 18.22...21.26 \text{ нФ}$; $C_{2B} = 1.951...2.225 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
PM	BB154	PHIL	var	$V_R > 30B$; $I_R (V_R = 30B) < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 18.5...21.25 \text{ нФ}$; $C_{2B} = 1.9...2.2 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
PN	BB190	PHIL	var	$V_R > 10B$; $I_R (V_R = 10B) < 0.003 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 18...20 \text{ нФ}$; $C_{2B} = 10.1...11.6 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
PP	CMD28L8	CSI	dz	$V_Z (I_Z = 0.5 \text{ мА}) = 6.8B$; $P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
QP	CMDZ7L5	CSI	dz	$V_Z (I_Z = 0.5 \text{ мА}) = 7.5B$; $P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
R (бен)	BA595	INF	pin	$V_R > 50B$; $I_R < 50 \text{ мА}$; $V_F (I_F = 50 \text{ мА}) < 1.1B$; $I_S < 0.02 \text{ мкА}$	SOD-323, SC-76	К*А
R2	MMS25272BT1	ON	dz	$V_Z (I_Z = 1.1 \text{ мА}) = 104.5...115.5B$; $I_S < 0.1 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
RF	CMD28L2	CSI	dz	$V_Z (I_Z = 0.5 \text{ мА}) = 8.2B$; $P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
S	BA582	INF	dtv	$V_R < 35B$; $I_R < 100 \text{ мА}$; $V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 1.0B$; $I_S < 0.02 \text{ мкА}$; $C_D < 1.1 \text{ нФ}$	SOD-123	К*А
S	BB515	SIEM	var	$V_R < 30B$; $I_R < 20 \text{ мА}$; $I_S < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 17.5...20 \text{ нФ}$; $C_{1B}/C_{2B} = 8.2...9.8$	SOD-123	К*А
S	BB619	SIEM	var	$V_R < 30B$; $I_R < 20 \text{ мА}$; $I_S < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 36...42 \text{ нФ}$; $C_{1B}/C_{2B} > 13.5$	SOD-123	К*А
S	BB619C	SIEM	var	$V_R < 30B$; $I_R < 20 \text{ мА}$; $I_S < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 36...42 \text{ нФ}$; $C_{1B}/C_{2B} > 13.5$	SOD-123	К*А
S	BB620	SIEM	var	$V_R < 30B$; $I_R < 20 \text{ мА}$; $I_S < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 62...76 \text{ нФ}$; $C_{1B}/C_{2B} = 19.5...25$	SOD-123	К*А
S (бен)	BB535	INF	var	$V_R < 30B$; $I_R < 20 \text{ мА}$; $I_S < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 17.5...20 \text{ нФ}$; $C_{1B}/C_{2B} = 8.2...9.8$	SOD-323, SC-76	К*А
S (жен)	BB639	INF	var	$V_R < 30B$; $I_R < 20 \text{ мА}$; $I_S < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 36...40 \text{ нФ}$; $C_{1B}/C_{2B} = 14.7$	SOD-323, SC-76	К*А
S (жен)	BB639C	INF	var	$V_R < 30B$; $I_R < 20 \text{ мА}$; $I_S < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 36.5...42 \text{ нФ}$; $C_{1B}/C_{2B} = 15.3$	SOD-323, SC-76	К*А
S (кра)	BB640	INF	var	$V_R < 30B$; $I_R < 20 \text{ мА}$; $I_S < 0.01 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 62...76 \text{ нФ}$; $C_{2B} = 2.8...3.3$	SOD-323, SC-76	К*А
S (снв)	BA592	INF	dtv	$V_R < 35B$; $I_R < 100 \text{ мА}$; $V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 1.0B$; $I_S < 0.02 \text{ мкА}$	SOD-323, SC-76	К*А
SZ	1SS315	TOSH	shd	$V_R < 5B$; $I_R < 30 \text{ мА}$; $V_F (I_F = 2 \text{ мА}) = 0.25B$; $I_R (V_R = 0.5B) < 25 \text{ мкА}$; $C_T = 0.6 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
S3	1SS357	TOSH	shd	$V_R > 40B$; $V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 0.6B$; $I_R (V_R = 40B) < 5 \text{ мкА}$	SOD-323, SC-76	К*А
S4	1SS367	TOSH	shd	$V_R > 10B$; $V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 0.5B$; $I_R (V_R = 10B) < 20 \text{ мкА}$	SOD-323, SC-76	К*А
S5	1SS404	TOSH	shd	$V_R > 20B$; $V_F (I_F = 300 \text{ мА}) < 0.45B$; $I_R (V_R = 20B) < 50 \text{ мкА}$; $C_T = 46 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
S6	SD103AW	VISH	shd	$V_R < 40B$; $V_F (I_F = 200 \text{ мА}) < 0.6B$; $C_D = 50 \text{ нФ}$	SOD-123	К*А
S7	BAT42W	DIODS	shd	$V_R < 30B$; $I_R < 200 \text{ мА}$; $V_F (I_F = 50 \text{ мА}) < 0.65 \text{ мВ}$; $C_D = 10 \text{ нФ}$	SOD-123	К*А
S7	BAT42W	TSC	shd	$V_R < 30B$; $I_R < 200 \text{ мА}$; $V_F (I_F = 50 \text{ мА}) < 0.65 \text{ мВ}$; $C_D = 10 \text{ нФ}$	SOD-123	К*А
S7	BAT42WS	DIODS	shd	$V_R < 30B$; $I_R < 200 \text{ мА}$; $V_F (I_F = 50 \text{ мА}) < 0.65 \text{ мВ}$; $C_D = 10 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
S7	SD103BW	VISH	shd	$V_R < 30B$; $V_F (I_F = 200 \text{ мА}) < 0.6B$; $C_D = 50 \text{ нФ}$	SOD-123	К*А
S8	BAT43W	DIODS	shd	$V_R < 30B$; $I_R < 200 \text{ мА}$; $V_F (I_F = 15 \text{ мА}) < 0.45 \text{ мВ}$; $C_D = 10 \text{ нФ}$	SOD-123	К*А
S8	BAT43W	TSC	shd	$V_R < 30B$; $I_R < 200 \text{ мА}$; $V_F (I_F = 15 \text{ мА}) < 0.45 \text{ мВ}$; $C_D = 10 \text{ нФ}$	SOD-123	К*А
S8	BAT43WS	DIODS	shd	$V_R < 30B$; $I_R < 200 \text{ мА}$; $V_F (I_F = 15 \text{ мА}) < 0.45 \text{ мВ}$; $C_D = 10 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
S8	SD103CW	VISH	shd	$V_R < 20B$; $V_F (I_F = 200 \text{ мА}) < 0.6B$; $C_D = 50 \text{ нФ}$	SOD-123	К*А
S9	BAT46W	DIODS	shd	$V_R < 100B$; $I_R < 150 \text{ мА}$; $V_F (I_F = 10 \text{ мА}) < 4.45 \text{ мВ}$; $C_D = 10 \text{ нФ}$	SOD-123	К*А
SA	SD101AW	VISH	shd	$V_R < 60B$; $I_R < 30 \text{ мА}$; $V_F (I_F = 15 \text{ мА}) < 0.45 \text{ мВ}$; $C_D < 2 \text{ нФ}$	SOD-123	К*А
SB	BAT54T1	ON	shd	$V_R < 30B$; $I_R < 200 \text{ мА}$; $V_F (I_F = 30 \text{ мА}) < 0.5B$; $t_{RR} < 5 \text{ нс}$	SOD-123	К*А
SB	SD101BW	VISH	shd	$V_R < 50B$; $I_R < 30 \text{ мА}$; $V_F (I_F = 15 \text{ мА}) < 0.95B$; $C_D < 2.1 \text{ нФ}$	SOD-123	К*А
SC	SD101CW	VISH	shd	$V_R < 40B$; $I_R < 30 \text{ мА}$; $V_F (I_F = 15 \text{ мА}) < 0.9B$; $C_D < 2.2 \text{ нФ}$	SOD-123	К*А
SP	CMD29L1	CSI	dz	$V_Z (I_Z = 0.5 \text{ мА}) = 9.1B$; $P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
T	BB811	SIEM	var	$V_R < 30B$; $I_R < 20 \text{ мА}$; $I_S < 0.02 \text{ мкА}$; $C_{1B} = 7.8...9.8 \text{ нФ}$; $C_{1B}/C_{2B} = 7.8...9.5$	SOD-123	К*А



DO215, SOD123/323



DO216AA

Код	Типонаимал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц1*2
T (син)	BAR67-03W	INF	pin	$V_R < 150 \text{ В}; I_F < 200 \text{ мА}; V_F (I_F = 50 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}; C_{25} < 0.9 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
T1	GDZ5V1B	VISH	dz	$V_2 = 5.1 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 80 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
T2	GDZ5V6B	VISH	dz	$V_2 = 5.6 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 60 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
T3	GDZ6V2B	VISH	dz	$V_2 = 6.2 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 60 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
T4	GDZ6v8B	VISH	dz	$V_2 = 6.8 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 40 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
T5	GDZ7V5B	VISH	dz	$V_2 = 7.5 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 30 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
T6	GDZ8V2B	VISH	dz	$V_2 = 8.2 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 30 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
T7	GDZ9V1B	VISH	dz	$V_2 = 9.1 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 30 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
T8	GDZ10B	VISH	dz	$V_2 = 10 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 30 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
T9	GDZ11B	VISH	dz	$V_2 = 11 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 30 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
TA	GDZ12B	VISH	dz	$V_2 = 12 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 30 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
TB	GDZ13B	VISH	dz	$V_2 = 13 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 37 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
TC	GDZ15B	VISH	dz	$V_2 = 15 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 42 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
TD	GDZ16B	VISH	dz	$V_2 = 16 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 50 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
TE	GDZ18B	VISH	dz	$V_2 = 18 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 65 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
TH	GDZ20B	VISH	dz	$V_2 = 20 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 85 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
TK	GDZ22B	VISH	dz	$V_2 = 22 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 100 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
TL	GDZ24B	VISH	dz	$V_2 = 24 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 120 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
TM	GDZ27B	VISH	dz	$V_2 = 27 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 150 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
TN	GDZ30B	VISH	dz	$V_2 = 30 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 200 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
TP	GDZ33B	VISH	dz	$V_2 = 33 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 250 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
TT	GDZ36B	VISH	dz	$V_2 = 36 \text{ В}; Z_{2T} (I_2 = 5 \text{ мА}) = 300 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
T1	MMSZ2V4T1	ON	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ мА}) = 2.28...2.52 \text{ В}; I_1 < 50 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
T2	1SV215	TOSH	var	$V_R > 30 \text{ В}; I_R (V_R = 28 \text{ В}) < 0.01 \text{ мА}; C_{25} = 26...32 \text{ нФ}; C_{25B} = 2.5...3.2 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
T2	BAV19W	DIODS	di	$V_R < 100 \text{ В}; I_F < 250 \text{ мА}; V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_0 < 5 \text{ нФ}; t_{RR} < 50 \text{ нс}$	SOD-123	К*А
T2	BAV20W	DIODS	di	$V_R < 150 \text{ В}; I_F < 250 \text{ мА}; V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_0 < 5 \text{ нФ}; t_{RR} < 50 \text{ нс}$	SOD-123	К*А
T2	BAV20W	TSC	di	$V_R < 150 \text{ В}; I_F < 400 \text{ мА}; V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_0 < 5 \text{ нФ}; t_{RR} < 50 \text{ нс}$	SOD-123	К*А
T2	BAV20W	MCC	di	$V_R < 150 \text{ В}; I_F < 400 \text{ мА}; V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_0 < 5 \text{ нФ}; t_{RR} < 50 \text{ нс}$	SOD-123	К*А
T2	MMSZ2V7T1	ON	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ мА}) = 2.57...2.84 \text{ В}; I_1 < 20 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
T3	1SV245	TOSH	var	$V_R > 30 \text{ В}; I_R (V_R = 28 \text{ В}) < 0.01 \text{ мА}; C_{25} = 3.31...4.55 \text{ нФ}; C_{25B} = 0.61...0.77 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
T3	BAV19W	DIODS	di	$V_R < 100 \text{ В}; I_F < 250 \text{ мА}; V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_0 < 5 \text{ нФ}; t_{RR} < 50 \text{ нс}$	SOD-123	К*А
T3	BAV20W	DIODS	di	$V_R < 150 \text{ В}; I_F < 250 \text{ мА}; V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_0 < 5 \text{ нФ}; t_{RR} < 50 \text{ нс}$	SOD-123	К*А
T3	BAV21W	DIODS	di	$V_R < 200 \text{ В}; I_F < 250 \text{ мА}; V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_0 < 5 \text{ нФ}; t_{RR} < 50 \text{ нс}$	SOD-123	К*А
T3	BAV21W	TSC	di	$V_R < 200 \text{ В}; I_F < 400 \text{ мА}; V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_0 < 5 \text{ нФ}; t_{RR} < 50 \text{ нс}$	SOD-123	К*А
T3	BAV21W	MCC	di	$V_R < 200 \text{ В}; I_F < 400 \text{ мА}; V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_0 < 5 \text{ нФ}; t_{RR} < 50 \text{ нс}$	SOD-123	К*А
T3	MMSZ3V0T1	ON	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ мА}) = 2.85...3.15 \text{ В}; I_1 < 10 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
T4	1N4148W	DIODS	sd	$V_R = 75 \text{ В}; I_F = 300 \text{ мА}; P_0 = 350 \text{ мВт}; t_{RR} < 4 \text{ нс}$	SOD-123	К*А
T4	1SV216	TOSH	var	$V_R > 30 \text{ В}; I_R (V_R = 28 \text{ В}) < 0.01 \text{ мА}; C_{25} = 10.5...16 \text{ нФ}; C_{10B} = 3.3...5.7 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
T4	MMSZ3V3T1	ON	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ мА}) = 3.14...3.47 \text{ В}; I_1 < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
T5	1N4448W	DIODS	sd	$V_R = 75 \text{ В}; I_F = 500 \text{ мА}; P_0 = 400 \text{ мВт}; t_{RR} < 4 \text{ нс}$	SOD-123	К*А
T5	MMSZ3V6T1	ON	dz	$V_2 (I_{2T} = 5 \text{ мА}) = 3.42...3.78 \text{ В}; I_1 < 5 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
T6	1SV217	TOSH	var	$V_R > 30 \text{ В}; I_R (V_R = 28 \text{ В}) < 0.01 \text{ мА}; C_{25} = 33...39 \text{ нФ}; C_{25B} = 2.6...3.2 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
T7	1SV230	TOSH	var	$V_R > 30 \text{ В}; I_R (V_R = 28 \text{ В}) < 0.01 \text{ мА}; C_{25} = 13.9...16.1 \text{ нФ}; C_{20B} = 1.7...2.1 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
T8	1SV229	TOSH	var	$V_R > 15 \text{ В}; I_R (V_R = 15 \text{ В}) < 0.003 \text{ мА}; C_{25} = 14...16 \text{ нФ}; C_{10B} = 5.5...6.5 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
T9	1SV232	TOSH	var	$V_R > 30 \text{ В}; I_R (V_R = 28 \text{ В}) < 0.01 \text{ мА}; C_{25} = 28...32 \text{ нФ}; C_{25B} = 2.75...3.1 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
TA	1SV231	TOSH	var	$V_R > 30 \text{ В}; I_R (V_R = 28 \text{ В}) < 0.01 \text{ мА}; C_{25} = 41...49.5 \text{ нФ}; C_{25B} = 2.7...3.4 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
TC	1SV239	TOSH	var	$V_R > 15 \text{ В}; I_R (V_R = 15 \text{ В}) < 0.003 \text{ мА}; C_{25} = 3.8...4.7 \text{ нФ}; C_{10B} = 1.5...2 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
TD	1SV262	TOSH	var	$V_R > 34 \text{ В}; I_R (V_R = 32 \text{ В}) < 0.01 \text{ мА}; C_{25} = 33...38 \text{ нФ}; C_{25B} = 2.6...3 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
TE	1SV269	TOSH	var	$V_R > 34 \text{ В}; I_R (V_R = 32 \text{ В}) < 0.01 \text{ мА}; C_{25} = 29...34 \text{ нФ}; C_{25B} = 2.5...2.9 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
TF	1SV270	TOSH	var	$V_R > 10 \text{ В}; I_R (V_R = 10 \text{ В}) < 0.003 \text{ мА}; C_{15} = 15...17 \text{ нФ}; C_{4B} = 7.3...8.7 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
TG	1SV271	TOSH	pin	$V_R > 50 \text{ В}; I_F < 50 \text{ мА}; V_F (I_F = 50 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_1 < 0.1 \text{ мА}$	SOD-323, SC-76	К*А
TH	1SV293	TOSH	var	$V_R > 10 \text{ В}; I_R (V_R = 10 \text{ В}) < 0.003 \text{ мА}; C_{15} = 18...20 \text{ нФ}; C_{4B} = 10...11.6 \text{ нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1-2
TJ	1SV214	TOSH	var	$V_R > 30\text{В}; I_n (V_R = 28\text{В}) < 0.01\text{мкА}; C_{25\text{В}} = 14.16...16.25\text{нФ}; C_{25\text{В}} = 2.11...2.43\text{нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
TJ	1SV288	TOSH	var	$V_R > 30\text{В}; I_n (V_R = 28\text{В}) < 0.01\text{мкА}; C_{25\text{В}} = 41...49.5\text{нФ}; C_{25\text{В}} = 2.5...3.2\text{нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
TK	1SV287	TOSH	var	$V_R > 30\text{В}; I_n (V_R = 28\text{В}) < 0.01\text{мкА}; C_{25\text{В}} = 4.2...5.7\text{нФ}; C_{25\text{В}} = 0.53...0.68\text{нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
TL	1SV276	TOSH	var	$V_R > 10\text{В}; I_n (V_R = 10\text{В}) < 0.003\text{мкА}; C_{1\text{В}} = 15...17\text{нФ}; C_{4\text{В}} = 7...8.5\text{нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
TO	1SV277	TOSH	var	$V_R > 10\text{В}; I_n (V_R = 10\text{В}) < 0.003\text{мкА}; C_{1\text{В}} = 4...4.9\text{нФ}; C_{4\text{В}} = 1.85...2.35\text{нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
TP	CMDZ10L	CSI	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 0.5\text{мА}) = 10\text{В}; P_0 < 250\text{мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
TT	1SV302	TOSH	var	$V_R > 30\text{В}; I_n (V_R = 28\text{В}) < 0.01\text{мкА}; C_{25\text{В}} = 42...51\text{нФ}; C_{25\text{В}} = 2.1...3.1\text{нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
TV	1SV304	TOSH	var	$V_R > 10\text{В}; I_n (V_R = 10\text{В}) < 0.003\text{мкА}; C_{1\text{В}} = 17.3...19.3\text{нФ}; C_{4\text{В}} = 5.3...6.6\text{нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
TX	1SV307	TOSH	pin	$V_R > 30\text{В}; I_n < 50\text{мА}; V_Z (I_Z = 50\text{мА}) < 1\text{В}; I_n < 0.1\text{мкА}$	SOD-323, SC-76	К*А
TY	1SS314	TOSH	di	$V_R < 30\text{В}; I_n < 100\text{мА}; V_Z (I_Z = 2\text{мА}) < 0.85\text{В}; I_n < 0.1\text{мкА}$	SOD-323, SC-76	К*А
U (6en)	BB545	INF	var	$V_R > 30\text{В}; I_n < 20\text{мА}; I_n < 0.01\text{мкА}; C_{1\text{В}} = 18.5...21.5\text{нФ}; C_{1\text{В}}/C_{25\text{В}} = 9...11$	SOD-323, SC-76	К*А
U1	MMSZ3V9T1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 3.71...4.10\text{В}; I_n < 3\text{мкА}$	SOD-123	К*А
U2	MMSZ4V3T1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 4.09...4.52\text{В}; I_n < 3\text{мкА}$	SOD-123	К*А
U3	MMSZ4V7T1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 4.47...4.94\text{В}; I_n < 2\text{мкА}$	SOD-123	К*А
U4	MMSZ5V1T1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 4.85...5.36\text{В}; I_n < 1\text{мкА}$	SOD-123	К*А
U5	MMSZ5V6T1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 5.32...5.88\text{В}; I_n < 3\text{мкА}$	SOD-123	К*А
UP	CMDZ11L	CSI	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 0.5\text{мА}) = 11\text{В}; P_0 < 250\text{мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
V1	1SV310	TOSH	var	$V_R > 10\text{В}; I_n (V_R = 10\text{В}) < 0.003\text{мкА}; C_{1\text{В}} = 9.7...11.1\text{нФ}; C_{4\text{В}} = 4.45...5.45\text{нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
V1	MMSZ6V2T1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 5.89...6.51\text{В}; I_n < 2\text{мкА}$	SOD-123	К*А
V2	1SV328	TOSH	var	$V_R > 10\text{В}; I_n (V_R = 10\text{В}) < 0.003\text{мкА}; C_{1\text{В}} = 5.7...6.7\text{нФ}; C_{4\text{В}} = 1.85...2.45\text{нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
V2	MMSZ6V8T1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 6.46...7.14\text{В}; I_n < 1\text{мкА}$	SOD-123	К*А
V3	MMSZ7V5T1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 7.13...7.88\text{В}; I_n < 0.7\text{мкА}$	SOD-123	К*А
V4	MMSZ8V2T1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 7.79...8.61\text{В}; I_n < 0.5\text{мкА}$	SOD-123	К*А
V5	MMSZ9V1T1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 8.65...9.56\text{В}; I_n < 0.2\text{мкА}$	SOD-123	К*А
V6	1SV313	TOSH	var	$V_R > 10\text{В}; I_n (V_R = 10\text{В}) < 0.003\text{мкА}; C_{0.5\text{В}} = 7.3...8.4\text{нФ}; C_{2.5\text{В}} = 2.75...3.4\text{нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
V7	1SV322	TOSH	var	$V_R > 10\text{В}; I_n (V_R = 10\text{В}) < 0.003\text{мкА}; C_{1\text{В}} = 26.5...29.5\text{нФ}; C_{4\text{В}} = 6...7.1\text{нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
V8	1SV324	TOSH	var	$V_R > 10\text{В}; I_n (V_R = 10\text{В}) < 0.003\text{мкА}; C_{1\text{В}} = 44...49.5\text{нФ}; C_{4\text{В}} = 9.2...12\text{нФ}$	SOD-323, SC-76	К*А
VP	CMDZ12L	CSI	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 0.5\text{мА}) = 12\text{В}; P_0 < 250\text{мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
W1	BZT52B2V4	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 2.35...2.45\text{В}; Z_{T1} < 85\text{Ом}$	SOD-123	К*А
W1	BZT52C2V4	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 2.2...2.8\text{В}; Z_{T1} < 85\text{Ом}$	SOD-123	К*А
W1	BZT52C2V7S	DIODS	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 2.5...2.9\text{В}; Z_{T1} < 100\text{Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W1	BZX384B2V4	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 2.35...2.45\text{В}; Z_{T1} < 100\text{Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W1	BZX384C2V4	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 2.2...2.6\text{В}; Z_{T1} < 100\text{Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W2	BZT52B2V7	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 2.65...2.75\text{В}; Z_{T1} < 83\text{Ом}$	SOD-123	К*А
W2	BZT52C2V7	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 2.5...2.9\text{В}; Z_{T1} < 83\text{Ом}$	SOD-123	К*А
W2	BZT52C3V0S	DIODS	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 2.8...3.2\text{В}; Z_{T1} < 95\text{Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W2	BZX384B2V7	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 2.65...2.75\text{В}; Z_{T1} < 100\text{Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W2	BZX384C2V7	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 2.5...2.9\text{В}; Z_{T1} < 100\text{Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W3	BZT52B3V0	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 2.94...3.06\text{В}; Z_{T1} < 95\text{Ом}$	SOD-123	К*А
W3	BZT52C3V0	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 2.8...3.2\text{В}; Z_{T1} < 95\text{Ом}$	SOD-123	К*А
W3	BZT52C3V3S	DIODS	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 3.1...3.5\text{В}; Z_{T1} < 95\text{Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W3	BZX384B3V0	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 2.94...3.06\text{В}; Z_{T1} < 95\text{Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W3	BZX384C3V0	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 2.8...3.2\text{В}; Z_{T1} < 95\text{Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W4	BZT52B3V3	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 3.23...3.37\text{В}; Z_{T1} < 95\text{Ом}$	SOD-123	К*А
W4	BZT52C3V3	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 3.1...3.5\text{В}; Z_{T1} < 95\text{Ом}$	SOD-123	К*А
W4	BZT52C3V6S	DIODS	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 3.4...3.8\text{В}; Z_{T1} < 90\text{Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W4	BZX384B3V3	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 3.23...3.37\text{В}; Z_{T1} < 95\text{Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W4	BZX384C3V3	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 3.1...3.5\text{В}; Z_{T1} < 95\text{Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W5	BZT52B3V6	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 3.53...3.67\text{В}; Z_{T1} < 95\text{Ом}$	SOD-123	К*А
W5	BZT52C3V6	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 3.4...3.8\text{В}; Z_{T1} < 95\text{Ом}$	SOD-123	К*А
W5	BZT52C3V9S	DIODS	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5\text{мА}) = 3.7...4.1\text{В}; Z_{T1} < 90\text{Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А



DO215, SOD123/323



DO216AA

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
W5	BZX384B3V6	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 3.53...3.67\text{ B}$; $Z_{T1} < 90\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W5	BZX384C3V6	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 3.4...3.8\text{ B}$; $Z_{T1} < 90\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W6	BZT52B3V9	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 3.82...3.98\text{ B}$; $Z_{T1} < 95\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
W6	BZT52C3V9	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 3.7...4.1\text{ B}$; $Z_{T1} < 95\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
W6	BZT52C4V3S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 4...4.6\text{ B}$; $Z_{T1} < 90\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W6	BZX384B3V9	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 3.82...3.98\text{ B}$; $Z_{T1} < 90\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W6	BZX384C3V9	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 3.7...4.1\text{ B}$; $Z_{T1} < 90\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W7	BZT52B4V3	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 4.21...4.39\text{ B}$; $Z_{T1} < 95\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
W7	BZT52C4V3	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 4...4.6\text{ B}$; $Z_{T1} < 95\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
W7	BZT52C4V7S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 4.4...5\text{ B}$; $Z_{T1} < 80\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W7	BZX384B4V3	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 4.21...4.39\text{ B}$; $Z_{T1} < 90\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W7	BZX384C4V3	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 4.0...4.6\text{ B}$; $Z_{T1} < 90\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W8	BZT52B4V7	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 4.61...4.79\text{ B}$; $Z_{T1} < 80\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
W8	BZT52C4V7	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 4.4...5\text{ B}$; $Z_{T1} < 80\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
W8	BZT52C5V1S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 4.8...5.4\text{ B}$; $Z_{T1} < 60\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W8	BZX384B4V7	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 4.61...4.79\text{ B}$; $Z_{T1} < 80\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W8	BZX384C4V7	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 4.4...5.0\text{ B}$; $Z_{T1} < 80\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W9	BZT52B5V1	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 5.0...5.2\text{ B}$; $Z_{T1} < 60\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
W9	BZT52C5V1	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 4.8...5.4\text{ B}$; $Z_{T1} < 60\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
W9	BZT52C5V6S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 5.2...6\text{ B}$; $Z_{T1} < 40\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W9	BZX384B5V1	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 5.0...5.2\text{ B}$; $Z_{T1} < 60\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
W9	BZX384C5V1	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 4.8...5.4\text{ B}$; $Z_{T1} < 60\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WA	BZT52B5V6	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 5.49...5.71\text{ B}$; $Z_{T1} < 40\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WA	BZT52C5V6	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 5.2...6\text{ B}$; $Z_{T1} < 40\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WA	BZT52C6V2S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 5.8...6.6\text{ B}$; $Z_{T1} < 10\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WA	BZX384B5V6	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 5.49...5.71\text{ B}$; $Z_{T1} < 40\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WA	BZX384C5V6	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 5.2...6\text{ B}$; $Z_{T1} < 40\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WA	SMZG3789A	GS	dz	$V_2(I_2 = 37.5\text{ mA}) = 10\text{ B} \pm 10\%$; $Z_{T1} = 5.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
WB	BZT52B6V2	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 6.08...6.32\text{ B}$; $Z_{T1} < 10\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WB	BZT52C6V2	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 5.8...6.6\text{ B}$; $Z_{T1} < 10\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WB	BZT52C6V8S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 6.4...7.2\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WB	BZX384B6V2	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 6.08...6.32\text{ B}$; $Z_{T1} < 10\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WB	BZX384C6V2	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 5.8...6.6\text{ B}$; $Z_{T1} < 10\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WB	SMZG3789B	GS	dz	$V_2(I_2 = 37.5\text{ mA}) = 10\text{ B} \pm 5\%$; $Z_{T1} = 5.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
WC	BZT52B6V8	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 6.66...6.94\text{ B}$; $Z_{T1} < 8\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WC	BZT52C6V8	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 6.4...7.2\text{ B}$; $Z_{T1} < 8\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WC	BZT52C7V5S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 7...7.9\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WC	BZX384B6V8	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 6.66...6.94\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WC	BZX384C6V8	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 6.4...7.2\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WC	SMZG3790A	GS	dz	$V_2(I_2 = 34.1\text{ mA}) = 11\text{ B} \pm 10\%$; $Z_{T1} = 6.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
WD	BZT52B7V5	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 7.35...7.65\text{ B}$; $Z_{T1} < 7\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WD	BZT52C7V5	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 7...7.9\text{ B}$; $Z_{T1} < 7\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WD	BZT52C8V2S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 7.7...8.7\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WD	BZX384B7V5	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 7.35...7.65\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WD	BZX384C7V5	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 7...7.5\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WD	SMZG3790B	GS	dz	$V_2(I_2 = 34.1\text{ mA}) = 11\text{ B} \pm 5\%$; $Z_{T1} = 6.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
WE	BZT52B8V2	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 8.04...8.36\text{ B}$; $Z_{T1} < 7\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WE	BZT52C8V2	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 7.7...8.7\text{ B}$; $Z_{T1} < 7\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WE	BZT52C9V1S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 8.5...9.6\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WE	BZX384B8V2	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 8.04...8.36\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WE	BZX384C8V2	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA}) = 7.7...8.7\text{ B}$; $Z_{T1} < 15\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WE	SMZG3791A	GS	dz	$V_2(I_2 = 31.2\text{ mA}) = 12\text{ B} \pm 10\%$; $Z_{T1} = 7.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1+2
WF	BZT5289V1	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=8.92...9.28\text{ B}; Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WF	BZT52C10S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=9.4...10.6\text{ B}; Z_{T1}<15\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WF	BZT52C9V1	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=8.5...9.6\text{ B}; Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WF	BZX38489V1	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=8.92...9.28\text{ B}; Z_{T1}<15\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WF	BZX384C9V1	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=8.5...9.6\text{ B}; Z_{T1}<15\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WF	SMZG3791B	GS	dz	$V_2(I_2=31.2\text{ mA})=12\text{ B}\pm 5\%; Z_{T1}=7.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
WG	BZT52B10	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=9.8...10.2\text{ B}; Z_{T1}<15\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WG	BZT52C10	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=9.4...10.6\text{ B}; Z_{T1}<15\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WG	BZT52C11S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=10.4...11.6\text{ B}; Z_{T1}<20\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WG	BZT52C12S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=11.4...12.7\text{ B}; Z_{T1}<20\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WG	BZT52C20S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=18.8...21.2\text{ B}; Z_{T1}<50\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WG	BZX384B10	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=9.8...10.2\text{ B}; Z_{T1}<20\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WG	BZX384C10	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=9.4...10.6\text{ B}; Z_{T1}<20\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WG	SMZG3792A	GS	dz	$V_2(I_2=28.8\text{ mA})=13\text{ B}\pm 10\%; Z_{T1}=7.5\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
WH	BZT52B11	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=10.8...11.2\text{ B}; Z_{T1}<20\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WH	BZT52C11	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=10.4...11.6\text{ B}; Z_{T1}<20\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WH	BZX384B11	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=10.8...11.2\text{ B}; Z_{T1}<20\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WH	BZX384C11	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=10.4...11.6\text{ B}; Z_{T1}<20\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WH	SMZG3792B	GS	dz	$V_2(I_2=28.8\text{ mA})=13\text{ B}\pm 5\%; Z_{T1}=7.5\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
WI	BZT52B12	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=11.8...12.2\text{ B}; Z_{T1}<20\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WI	BZT52C12	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=11.4...12.7\text{ B}; Z_{T1}<20\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WI	BZT52C13S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=12.4...14.1\text{ B}; Z_{T1}<25\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WI	BZX384B12	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=11.8...12.2\text{ B}; Z_{T1}<25\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WI	BZX384C12	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=11.4...12.7\text{ B}; Z_{T1}<25\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WI	SMZG3793A	GS	dz	$V_2(I_2=25.0\text{ mA})=15\text{ B}\pm 10\%; Z_{T1}=9.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
WJ	BZT52C15S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=13.8...15.6\text{ B}; Z_{T1}<25\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WJ	SMZG3793B	GS	dz	$V_2(I_2=25.0\text{ mA})=15\text{ B}\pm 5\%; Z_{T1}=9.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
WK	BZT52B13	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=12.7...13.3\text{ B}; Z_{T1}<25\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WK	BZT52C13	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=12.4...14.1\text{ B}; Z_{T1}<25\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WK	BZT52C16S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=15.3...17.1\text{ B}; Z_{T1}<40\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WK	BZX384B13	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=12.7...13.3\text{ B}; Z_{T1}<30\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WK	BZX384C13	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=12.4...14.1\text{ B}; Z_{T1}<30\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WK	SMZG3794A	GS	dz	$V_2(I_2=23.4\text{ mA})=16\text{ B}\pm 10\%; Z_{T1}=10.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
WL	BZT52B15	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=14.7...15.3\text{ B}; Z_{T1}<30\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WL	BZT52C15	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=13.8...15.6\text{ B}; Z_{T1}<30\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WL	BZT52C18S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=16.8...19.1\text{ B}; Z_{T1}<50\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WL	BZX384B15	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=14.7...15.3\text{ B}; Z_{T1}<30\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WL	BZX384C15	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=13.8...15.6\text{ B}; Z_{T1}<30\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WL	SMZG3794B	GS	dz	$V_2(I_2=23.4\text{ mA})=16\text{ B}\pm 5\%; Z_{T1}=10.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
WM	BZT52B16	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=15.7...16.3\text{ B}; Z_{T1}<40\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WM	BZT52C16	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=15.3...17.1\text{ B}; Z_{T1}<40\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WM	BZX384B16	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=15.7...16.3\text{ B}; Z_{T1}<40\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WM	BZX384C16	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=15.3...17.1\text{ B}; Z_{T1}<40\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WN	BZT52B18	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=17.6...18.4\text{ B}; Z_{T1}<50\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WN	BZT52C18	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=16.8...19.1\text{ B}; Z_{T1}<50\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WN	BZT52C22S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=21.6...22.4\text{ B}; Z_{T1}<55\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WN	BZX384B18	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=17.6...18.4\text{ B}; Z_{T1}<45\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WN	BZX384C18	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=16.8...19.1\text{ B}; Z_{T1}<45\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WO	BZT52B20	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=19.6...20.4\text{ B}; Z_{T1}<50\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WO	BZT52C20	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=18.8...21.2\text{ B}; Z_{T1}<50\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
WO	BZT52C24S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=22.8...23.3\text{ B}; Z_{T1}<80\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
WO	BZX384B20	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=19.6...20.4\text{ B}; Z_{T1}<50\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А



DO215, SOD123/323



DO216AA

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
WO	BZX384C20	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=18.8...21.2\text{B}$; $Z_{T1}<55\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WP	BZT52B22	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=21.6...22.4\text{B}$; $Z_{T1}<55\text{Om}$	SOD-123	К*А
WP	BZT52C22	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=21.6...22.4\text{B}$; $Z_{T1}<55\text{Om}$	SOD-123	К*А
WP	BZT52C27S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=25.1...28.9\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WP	BZX384B22	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=21.6...22.4\text{B}$; $Z_{T1}<55\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WP	BZX384C22	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=20.8...23.3\text{B}$; $Z_{T1}<55\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WQ	BZT52C30S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=28...32\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WR	BZT52B24	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=23.5...24.5\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-123	К*А
WR	BZT52C24	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=22.8...23.3\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-123	К*А
WR	BZT52C33S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=31...35\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WR	BZX384B24	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=23.5...24.5\text{B}$; $Z_{T1}<70\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WR	BZX384C24	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=22.8...25.6\text{B}$; $Z_{T1}<70\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WS	BZT52B27	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=26.5...27.5\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-123	К*А
WS	BZT52C27	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=25.1...28.9\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-123	К*А
WS	BZT52C36S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=34...38\text{B}$; $Z_{T1}<90\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WS	BZX384B27	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=26.5...27.5\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WS	BZX384C27	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=25.1...28.9\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WT	BZT52B30	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=29.4...30.6\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-123	К*А
WT	BZT52C30	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=28...32\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-123	К*А
WT	BZT52C39S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=37...41\text{B}$; $Z_{T1}<130\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WT	BZX384B30	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=29.4...30.6\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WT	BZX384C30	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=28...32\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WU	BZT52B33	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=32.3...33.7\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-123	К*А
WU	BZT52C33	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=31...35\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-123	К*А
WU	BZX384B33	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=32.3...33.7\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WU	BZX384C33	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=31...35\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WW	BZT52B36	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=35.3...36.7\text{B}$; $Z_{T1}<90\text{Om}$	SOD-123	К*А
WW	BZT52C36	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=34...38\text{B}$; $Z_{T1}<90\text{Om}$	SOD-123	К*А
WW	BZX384B36	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=35.3...36.7\text{B}$; $Z_{T1}<90\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WW	BZX384C36	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=34...38\text{B}$; $Z_{T1}<90\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WX	BZT52B39	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=38.2...39.8\text{B}$; $Z_{T1}<90\text{Om}$	SOD-123	К*А
WX	BZT52C2V4S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=2.2...2.6\text{B}$; $Z_{T1}<100\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WX	BZT52C39	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=37...41\text{B}$; $Z_{T1}<90\text{Om}$	SOD-123	К*А
WX	BZX384B39	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=38.2...39.8\text{B}$; $Z_{T1}<130\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WX	BZX384C39	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=37...41\text{B}$; $Z_{T1}<130\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WY	BZT52B43	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=42.1...43.9\text{B}$; $Z_{T1}<100\text{Om}$	SOD-123	К*А
WY	BZT52C2V0S	DIODS	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=1.91...2.09\text{B}$; $Z_{T1}<100\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WY	BZT52C43	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=40...46\text{B}$; $Z_{T1}<100\text{Om}$	SOD-123	К*А
WY	BZX384B43	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=42.1...43.9\text{B}$; $Z_{T1}<150\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WY	BZX384C43	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=40...46\text{B}$; $Z_{T1}<130\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WZ	BZT52B47	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=46.1...47.9\text{B}$; $Z_{T1}<100\text{Om}$	SOD-123	К*А
WZ	BZT52C47	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=44...50\text{B}$; $Z_{T1}<100\text{Om}$	SOD-123	К*А
WZ	BZX384B47	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=46.1...47.9\text{B}$; $Z_{T1}<170\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
WZ	BZX384C47	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=44...50\text{B}$; $Z_{T1}<150\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
X (Gen)	B8833	INF	var	$V_R < 30\text{B}$; $I_F < 20\text{mA}$; $I_{FS} < 0.02\text{mA}$; $C_{1B} = 8.5...10\text{нФ}$; $C_{28B} = 0.6...0.9$	SOD-323, SC-76	К*А
X (xen)	B8835	INF	var	$V_R < 30\text{B}$; $I_F < 20\text{mA}$; $I_{FS} < 0.02\text{mA}$; $C_{1B} = 8.5...10\text{нФ}$; $C_{28B} = 0.5...0.75$	SOD-323, SC-76	К*А
X1	BZT52B51	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=50.0...52.0\text{B}$; $Z_{T1}<100\text{Om}$	SOD-123	К*А
X1	BZT52C51	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=48...54\text{B}$; $Z_{T1}<100\text{Om}$	SOD-123	К*А
X1	BZX384B51	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=50.0...52.0\text{B}$; $Z_{T1}<180\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
X1	BZX384C51	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{mA})=48...54\text{B}$; $Z_{T1}<180\text{Om}$	SOD-323, SC-76	К*А
X1	CMDZ5221B	CSI	dz	$V_2 = 2.4\text{B}$ (5%); $P_D < 250\text{мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
X1	MMS216T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{mA})=15.2...16.8\text{B}$; $I_F < 0.05\text{mA}$	SOD-123	К*А



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1+2
X2	BZT52B56	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2.5\text{ mA})=54.9...57.1\text{ B}$; $Z_{T1} < 135\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
X2	BZT52C56	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2.5\text{ mA})=52...60\text{ B}$; $Z_{T1} < 135\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
X2	BZX384B56	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{ mA})=54.9...57.1\text{ B}$; $Z_{T1} < 200\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
X2	BZX384C56	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{ mA})=52...60\text{ B}$; $Z_{T1} < 200\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
X2	CMDZ5222B	CSI	dz	$V_2=2.5\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
X2	MMS218T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=17.1...18.9\text{ B}$; $I_R < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
X3	BZT52B62	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2.5\text{ mA})=60.8...63.2\text{ B}$; $Z_{T1} < 135\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
X3	BZT52C62	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2.5\text{ mA})=58...66\text{ B}$; $Z_{T1} < 135\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
X3	BZX384B62	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{ mA})=60.8...63.2\text{ B}$; $Z_{T1} < 215\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
X3	BZX384C62	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{ mA})=58...66\text{ B}$; $Z_{T1} < 215\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
X3	CMDZ5223B	CSI	dz	$V_2=2.7\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
X3	MMS220T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=19.0...21.0\text{ B}$; $I_R < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
X4	BZT52B68	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2.5\text{ mA})=66.6...69.4\text{ B}$; $Z_{T1} < 200\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
X4	BZT52C68	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2.5\text{ mA})=64...72\text{ B}$; $Z_{T1} < 200\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
X4	BZX384B68	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{ mA})=66.6...69.4\text{ B}$; $Z_{T1} < 240\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
X4	BZX384C68	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{ mA})=64...72\text{ B}$; $Z_{T1} < 240\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
X4	CMDZ5224B	CSI	dz	$V_2=2.8\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
X4	MMS222T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=20.9...23.1\text{ B}$; $I_R < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
X5	BZT52B75	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2.5\text{ mA})=73.5...76.5\text{ B}$; $Z_{T1} < 250\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
X5	BZT52C75	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2.5\text{ mA})=70...79\text{ B}$; $Z_{T1} < 250\text{ Ом}$	SOD-123	К*А
X5	BZX384B75	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{ mA})=73.5...76.5\text{ B}$; $Z_{T1} < 255\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
X5	BZX384C75	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=2\text{ mA})=70...79\text{ B}$; $Z_{T1} < 255\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
X5	CMDZ5225B	CSI	dz	$V_2=3.0\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
X5	MMS224T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=22.8...25.2\text{ B}$; $I_R < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
X6	CMDZ5226B	CSI	dz	$V_2=3.3\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
X6	CMDZ5227B	CSI	dz	$V_2=3.6\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
X8	CMDZ5228B	CSI	dz	$V_2=3.9\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
X9	CMDZ5229B	CSI	dz	$V_2=4.3\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XA	CMDZ5230B	CSI	dz	$V_2=4.7\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XA	SMZG3795A	GS	dz	$V_2(I_2=20.8\text{ mA})=18\text{ B} \pm 10\%$; $Z_{T1}=12.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
XB	CMDZ5231B	CSI	dz	$V_2=5.1\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XB	SMZG3795B	GS	dz	$V_2(I_2=20.8\text{ mA})=18\text{ B} \pm 5\%$; $Z_{T1}=12.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
XC	CMDZ5232B	CSI	dz	$V_2=5.6\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XC	SMZG3796A	GS	dz	$V_2(I_2=18.7\text{ mA})=20\text{ B} \pm 10\%$; $Z_{T1}=14.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
XD	CMDZ5233B	CSI	dz	$V_2=6.0\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XD	SMZG3796B	GS	dz	$V_2(I_2=18.7\text{ mA})=20\text{ B} \pm 5\%$; $Z_{T1}=14.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
XE	CMDZ5234B	CSI	dz	$V_2=6.2\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XE	SMZG3797A	GS	dz	$V_2(I_2=17.0\text{ mA})=22\text{ B} \pm 10\%$; $Z_{T1}=17.5\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
XF	CMDZ5235B	CSI	dz	$V_2=6.8\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XF	SMZG3797B	GS	dz	$V_2(I_2=17.0\text{ mA})=22\text{ B} \pm 5\%$; $Z_{T1}=17.5\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
XG	CMDZ5236B	CSI	dz	$V_2=7.5\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XG	SMZG3798A	GS	dz	$V_2(I_2=15.6\text{ mA})=24\text{ B} \pm 10\%$; $Z_{T1}=19.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
XH	CMDZ5237B	CSI	dz	$V_2=8.2\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XH	MMSD701T1	ON	shd	$V_R < 70\text{ B}$; $V_F(I_F=10\text{ mA}) < 1\text{ B}$; $C_D < 1\text{ нФ}$	SOD-123	К*А
XH	SMZG3798B	GS	dz	$V_2(I_2=15.6\text{ mA})=24\text{ B} \pm 5\%$; $Z_{T1}=19.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
XI	SMZG3799A	GS	dz	$V_2(I_2=13.9\text{ mA})=27\text{ B} \pm 10\%$; $Z_{T1}=23.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
XJ	CMDZ5238B	CSI	dz	$V_2=8.7\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XJ	SMZG3799B	GS	dz	$V_2(I_2=13.9\text{ mA})=27\text{ B} \pm 5\%$; $Z_{T1}=23.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
KK	CMDZ5239B	CSI	dz	$V_2=9.1\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
KK	SMZG3800A	GS	dz	$V_2(I_2=12.5\text{ mA})=30\text{ B} \pm 10\%$; $Z_{T1}=26.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
XL	CMDZ5240B	CSI	dz	$V_2=10\text{ B (5\%)}$; $P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XL	SMZG3800B	GS	dz	$V_2(I_2=12.5\text{ mA})=30\text{ B} \pm 5\%$; $Z_{T1}=26.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А

**DO215, SOD123/323****DO216AA**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
XN	CMDZ5241B	CSI	dz	$V_2 = 11 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XO	CMDZ5242B	CSI	dz	$V_2 = 12 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XP	CMDZ13L	CSI	dz	$V_2(I_{ZT} = 0.5 \text{ mA}) = 13 \text{ В; } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XP	CMDZ5243B	CSI	dz	$V_2 = 13 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XQ	CMDZ5244B	CSI	dz	$V_2 = 14 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XR	CMDZ5245B	CSI	dz	$V_2 = 15 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XS	CMDZ5246B	CSI	dz	$V_2 = 16 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XT	CMDZ5247B	CSI	dz	$V_2 = 17 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XT	MMSD301T1	ON	shd	$V_B < 30 \text{ В; } V_C(I_C = 10 \text{ mA}) < 0.6 \text{ В; } C_D < 1.5 \text{ нФ}$	SOD-123	К*А
XU	CMDZ5248B	CSI	dz	$V_2 = 18 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XV	CMDZ5249B	CSI	dz	$V_2 = 19 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XX	CMDZ5250B	CSI	dz	$V_2 = 20 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XY	CMDZ5251B	CSI	dz	$V_2 = 22 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
XZ	CMDZ5252B	CSI	dz	$V_2 = 24 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
Y1	CMDZ5253B	CSI	dz	$V_2 = 25 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
Y1	MMSZ2771	ON	dz	$V_2(I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 25.65...28.35 \text{ В; } I_B < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
Y2	CMDZ5254B	CSI	dz	$V_2 = 27 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
Y2	MMSZ30T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 28.50...31.5 \text{ В; } I_B < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
Y3	CMDZ5255B	CSI	dz	$V_2 = 28 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
Y3	MMSZ33T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 31.35...34.65 \text{ В; } I_B < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
Y4	CMDZ5256B	CSI	dz	$V_2 = 30 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
Y4	MMSZ36T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 34.2...37.8 \text{ В; } I_B < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
Y5	CMDZ5257B	CSI	dz	$V_2 = 33 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
Y5	MMSZ39T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 37.05...41.0 \text{ В; } I_B < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
Y6	CMDZ5258B	CSI	dz	$V_2 = 36 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
Y7	CMDZ5259B	CSI	dz	$V_2 = 39 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
Y8	CMDZ5260B	CSI	dz	$V_2 = 43 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
Y9	CMDZ5261B	CSI	dz	$V_2 = 47 \text{ В (5\%); } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
YA	SMZG3801A	GS	dz	$V_2(I_2 = 11.4 \text{ mA}) = 33 \text{ В} \pm 10\%; Z_{ZT} = 33.0 \text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
YB	SMZG3801B	GS	dz	$V_2(I_2 = 11.4 \text{ mA}) = 33 \text{ В} \pm 5\%; Z_{ZT} = 33.0 \text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
YC	SMZG3802A	GS	dz	$V_2(I_2 = 10.4 \text{ mA}) = 36 \text{ В} \pm 10\%; Z_{ZT} = 38.0 \text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
YD	SMZG3802B	GS	dz	$V_2(I_2 = 10.4 \text{ mA}) = 36 \text{ В} \pm 5\%; Z_{ZT} = 38.0 \text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
YE	SMZG3803A	GS	dz	$V_2(I_2 = 9.6 \text{ mA}) = 39 \text{ В} \pm 10\%; Z_{ZT} = 45.0 \text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
YF	SMZG3803B	GS	dz	$V_2(I_2 = 9.6 \text{ mA}) = 39 \text{ В} \pm 5\%; Z_{ZT} = 45.0 \text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
YG	SMZG3804A	GS	dz	$V_2(I_2 = 8.7 \text{ mA}) = 43 \text{ В} \pm 10\%; Z_{ZT} = 53.0 \text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
YH	SMZG3804B	GS	dz	$V_2(I_2 = 8.7 \text{ mA}) = 43 \text{ В} \pm 5\%; Z_{ZT} = 53.0 \text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
YI	SMZG3805A	GS	dz	$V_2(I_2 = 8.0 \text{ mA}) = 47 \text{ В} \pm 10\%; Z_{ZT} = 67.0 \text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
YJ	SMZG3805B	GS	dz	$V_2(I_2 = 8.0 \text{ mA}) = 47 \text{ В} \pm 5\%; Z_{ZT} = 67.0 \text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
YK	SMZG3806A	GS	dz	$V_2(I_2 = 7.3 \text{ mA}) = 51 \text{ В} \pm 10\%; Z_{ZT} = 70.0 \text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
YL	SMZG3806B	GS	dz	$V_2(I_2 = 7.3 \text{ mA}) = 51 \text{ В} \pm 5\%; Z_{ZT} = 70.0 \text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
YP	CMDZ15L	CSI	dz	$V_2(I_{ZT} = 0.5 \text{ mA}) = 15 \text{ В; } P_D < 250 \text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
Z0	PDZ2.4B	PHIL	dz	$V_2 = 2.4 \text{ В; } Z_{ZT}(I_2 = 5 \text{ mA}) = 100 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
Z1	MMSZ43T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 40.85...45.15 \text{ В; } I_B < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
Z1	PDZ2.7B	PHIL	dz	$V_2 = 2.7 \text{ В; } Z_{ZT}(I_2 = 5 \text{ mA}) = 100 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
Z2	MMSZ47T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 44.65...49.35 \text{ В; } I_B < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
Z2	PDZ3.0B	PHIL	dz	$V_2 = 3.0 \text{ В; } Z_{ZT}(I_2 = 5 \text{ mA}) = 95 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
Z3	MMSZ51T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 48.45...53.55 \text{ В; } I_B < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
Z3	PDZ3.3B	PHIL	dz	$V_2 = 3.3 \text{ В; } Z_{ZT}(I_2 = 5 \text{ mA}) = 95 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
Z4	MMSZ56T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 53.20...58.80 \text{ В; } I_B < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
Z4	PDZ3.6B	PHIL	dz	$V_2 = 3.6 \text{ В; } Z_{ZT}(I_2 = 5 \text{ mA}) = 90 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
Z5	MMSZ62T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT} = 5 \text{ mA}) = 57.00...63.00 \text{ В; } I_B < 0.05 \text{ мкА}$	SOD-123	К*А
Z5	PDZ3.9B	PHIL	dz	$V_2 = 3.9 \text{ В; } Z_{ZT}(I_2 = 5 \text{ mA}) = 90 \text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1+2
Z6	MMSZ68T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=64.60\dots71.40\text{ В}; I_T < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
Z6	PDZ4.3B	PHIL	dz	$V_2=4.3\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=90\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
Z7	MMSZ75T1	ON	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=71.25\dots78.75\text{ В}; I_T < 0.05\text{ мкА}$	SOD-123	К*А
Z7	PDZ4.7B	PHIL	dz	$V_2=4.7\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=90\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
Z8	PDZ5.1B	PHIL	dz	$V_2=5.1\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=60\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
Z9	PDZ5.6B	PHIL	dz	$V_2=5.6\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=50\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZA	PDZ6.2B	PHIL	dz	$V_2=6.2\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=50\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZA	SMZG3807A	GS	dz	$V_2(I_2=6.7\text{ mA})=56\text{ В} \pm 10\%; Z_{T1}=86.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
ZB	PDZ6.8B	PHIL	dz	$V_2=6.8\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=40\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZB	SMZG3807B	GS	dz	$V_2(I_2=6.7\text{ mA})=56\text{ В} \pm 5\%; Z_{T1}=86.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
ZC	PDZ7.5B	PHIL	dz	$V_2=7.5\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=10\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZC	SMZG3808A	GS	dz	$V_2(I_2=6.0\text{ mA})=62\text{ В} \pm 10\%; Z_{T1}=100.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
ZD	PDZ8.2B	PHIL	dz	$V_2=8.2\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=10\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZD	SMZG3808B	GS	dz	$V_2(I_2=6.0\text{ mA})=62\text{ В} \pm 5\%; Z_{T1}=100.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
ZE	PDZ9.1B	PHIL	dz	$V_2=9.1\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=10\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZE	SMZG3809A	GS	dz	$V_2(I_2=5.5\text{ mA})=68\text{ В} \pm 10\%; Z_{T1}=120.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
ZF	PDZ10B	PHIL	dz	$V_2=10\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=10\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZF	SMZG3809B	GS	dz	$V_2(I_2=5.5\text{ mA})=68\text{ В} \pm 5\%; Z_{T1}=120.0\text{ Ом}$	DO-215AA	К*А
ZG	PDZ11B	PHIL	dz	$V_2=11\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=10\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZH	PDZ12B	PHIL	dz	$V_2=12\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=10\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZJ	PDZ13B	PHIL	dz	$V_2=13\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=10\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZK	PDZ15B	PHIL	dz	$V_2=15\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=15\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZL	PDZ16B	PHIL	dz	$V_2=16\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=20\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZM	PDZ18B	PHIL	dz	$V_2=18\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=20\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZN	PDZ20B	PHIL	dz	$V_2=20\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=20\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZP	CMDZ16L	CSI	dz	$V_2(I_{ZT}=0.5\text{ mA})=16\text{ В}; P_D < 250\text{ мВт}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZP	PDZ22B	PHIL	dz	$V_2=22\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=25\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZQ	PDZ24B	PHIL	dz	$V_2=24\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=30\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZR	PDZ27B	PHIL	dz	$V_2=27\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=40\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZS	PDZ30B	PHIL	dz	$V_2=30\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=40\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZT	PDZ33B	PHIL	dz	$V_2=33\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=40\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А
ZU	PDZ36B	PHIL	dz	$V_2=36\text{ В}; Z_{T1}(I_2=5\text{ mA})=60\text{ Ом}$	SOD-323, SC-76	К*А

SOD623
SOD723- SOD523
SCD80- SOD219AB
SMF

SOD523/623/723, DO219, SMF

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
1	BA277	PHIL	dtv	$V_R < 35 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}; V_F (I_F = 10 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.05 \text{ мкА}; C_{D3} < 1.2 \text{ пФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
2	BB182	PHIL	var	$V_R > 32 \text{ В}; I_R (V_R = 30 \text{ В}) < 0.01 \text{ мкА}; C_{1B} = 52...62 \text{ пФ}; C_{2B8} = 2.48...2.89 \text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
2	BB182	LRC	var	$V_R > 32 \text{ В}; I_R (V_R = 30 \text{ В}) < 0.01 \text{ мкА}; C_{1B} = 52...62 \text{ пФ}; C_{2B8} = 2.48...2.89 \text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
5	BA892	PHIL	dtv	$V_R < 35 \text{ В}; I_R < 10 \text{ мА}; V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.02 \text{ мкА}$	SOD-523, SC-79	К*А
7	BBY55-02V	INF	var	$V_R < 16 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_S < 0.003 \text{ мкА}; C_{1B} = 17.5...19.6 \text{ нФ}; C_{10B} = 5.5...6.5 \text{ пФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
8	BB178	PHIL	var	$V_R > 32 \text{ В}; I_R (V_R = 30 \text{ В}) < 0.01 \text{ мкА}; C_{1B} = 34.65...42.35 \text{ пФ}; C_{2B8} = 2.361...2.754 \text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
8	BB178	LRC	var	$V_R > 32 \text{ В}; I_R (V_R = 30 \text{ В}) < 0.01 \text{ мкА}; C_{1B} = 34.65...42.35 \text{ пФ}; C_{2B8} = 2.361...2.754 \text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
8	BBY58-02V	INF	var	$V_R < 10 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_S < 0.01 \text{ мкА}; C_{1B} = 17.5...19.3 \text{ нФ}; C_{4B} = 5.5...6.6 \text{ пФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
9	BB179	PHIL	var	$V_R > 30 \text{ В}; I_R (V_R = 30 \text{ В}) < 0.01 \text{ мкА}; C_{1B} = 18.22...21.26 \text{ нФ}; C_{2B8} = 1.951...2.225 \text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
9	BB179	LRC	var	$V_R > 30 \text{ В}; I_R (V_R = 30 \text{ В}) < 0.01 \text{ мкА}; C_{1B} = 18.22...21.26 \text{ нФ}; C_{2B8} = 1.951...2.225 \text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
64	BAT64-02W	INF	shd	$V_R < 40 \text{ В}; I_R < 250 \text{ мА}; V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 0.75 \text{ В}; I_S < 2 \text{ мА}; C_D < 6 \text{ пФ}$	SCD-80	К*А
66	BBY56-02W	INF	var	$V_R < 10 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_S < 0.005 \text{ мкА}; C_{1B} = 37...43 \text{ пФ}; C_{4B} = 12.1 \text{ нФ}$	SCD-80	К*А
77	BBY55-02W	INF	var	$V_R < 16 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_S < 0.003 \text{ мкА}; C_{1B} = 17.5...19.6 \text{ нФ}; C_{10B} = 5.5...6.5 \text{ пФ}$	SCD-80	К*А
81	ZMV831BV2	ZETEX	var	$V_R < 25 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; I_S < 0.02 \text{ мкА}; C_{2B} = 14.25...15.75 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{20B} = 4.5...6.0$	SOD-523, SC-79	К*А
82	ZMV832BV2	ZETEX	var	$V_R < 25 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; I_S < 0.02 \text{ мкА}; C_{2B} = 20.9...23.1 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{20B} = 5...6.5$	SOD-523, SC-79	К*А
88	BBY58-02W	INF	var	$V_R < 10 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_S < 0.01 \text{ мкА}; C_{1B} = 17.5...19.3 \text{ нФ}; C_{4B} = 5.5...6.6 \text{ пФ}$	SCD-80	К*А
91	ZV931V2	ZETEX	var	$V_R < 12 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_{2.5B} = 6.5...7.8 \text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
92	ZV932V2	ZETEX	var	$V_R < 12 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_{2.5B} = 8.5...10.5 \text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
93	ZV933V2	ZETEX	var	$V_R < 12 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_{2.5B} = 18...27 \text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
0	BZX584CSV6-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 5.2...6 \text{ В}; Z_{T1} < 40 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
0	JDS2503S	TOSH	di	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}; V_F (I_F = 2 \text{ мА}) < 0.85 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 1.2 \text{ пФ}$	SOD-623	К*А
1	BZX584C16-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 15.3...17.1 \text{ В}; Z_{T1} < 40 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
1	BZX584C22-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 21.5...22.4 \text{ В}; Z_{T1} < 55 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
1	BZX584CSV1-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 4.8...5.4 \text{ В}; Z_{T1} < 60 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
1	BZX584CSV2-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 5.8...6.6 \text{ В}; Z_{T1} < 10 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
2	BZX584C18-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 16.8...19.1 \text{ В}; Z_{T1} < 45 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
2	BZX584C2V4-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 2.2...2.6 \text{ В}; Z_{T1} < 100 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
2	BZX584CSV8-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 6.4...7.2 \text{ В}; Z_{T1} < 15 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
3	BZX584C2V7-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 2.5...2.9 \text{ В}; Z_{T1} < 100 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
3	BZX584C7V5-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 7...7.9 \text{ В}; Z_{T1} < 15 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
4	BB664-02V	INF	var	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_S < 0.01 \text{ мкА}; C_{1B} = 39...44.5 \text{ нФ}; C_{2B8} = 2.4...2.75$	SOD-523, SC-79	К*А
4	BZX584C15-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 13.8...15.6 \text{ В}; Z_{T1} < 30 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
4	BZX584C20-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 18.8...21.2 \text{ В}; Z_{T1} < 55 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
4	BZX584C3V0-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 2.8...3.2 \text{ В}; Z_{T1} < 95 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
44	BB664	INF	var	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_S < 0.01 \text{ мкА}; C_{1B} = 39...44.5 \text{ нФ}; C_{2B8} = 2.4...2.75$	SCD-80	К*А
5	BBY57-02V	INF	var	$V_R < 10 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_S < 0.01 \text{ мкА}; C_{1B} = 16.5...18.6 \text{ нФ}; C_{4B} = 3.5...5.5 \text{ пФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
5	BZX584C13-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 12.4...14.1 \text{ В}; Z_{T1} < 30 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
5	BZX584C24-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 22.8...23.3 \text{ В}; Z_{T1} < 70 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
5	BZX584C3V3-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 3.1...3.5 \text{ В}; Z_{T1} < 95 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
55	BBY57-02W	INF	var	$V_R < 10 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_S < 0.01 \text{ мкА}; C_{1B} = 16.5...18.6 \text{ нФ}; C_{4B} = 3.5...5.5 \text{ пФ}$	SCD-80	К*А
6	BAS16-02V	INF	di	$V_R < 80 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; V_F (I_F = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_S < 50 \text{ мкА}$	SOD-523, SC-79	К*А
6	BZX584C3V6-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 3.4...3.8 \text{ В}; Z_{T1} < 90 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
62	BAT62-02W	INF	shd	$V_R < 40 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; V_F (I_F = 2 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_S < 10 \text{ мкА}; C_D < 0.6 \text{ пФ}$	SCD-80	К*А
7	BZX584C12-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 11.4...12.7 \text{ В}; Z_{T1} < 25 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
7	BZX584C27-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 2 \text{ мА}) = 25.1...28.9 \text{ В}; Z_{T1} < 80 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
7	BZX584C3V9-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 3.7...4.1 \text{ В}; Z_{T1} < 90 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
73	BAS70-02W	INF	shd	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 70 \text{ мА}; V_F (I_F = 15 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ пФ}$	SCD-80	К*А
8	BZX584C4V3-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5 \text{ мА}) = 4.0...4.6 \text{ В}; Z_{T1} < 90 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А

– SOD623
SOD723

– SOD523
SCD80

– SOD219AB
SMF



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1+2
9	BZX584C33-02V	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=2\text{mA})=31...35\text{B}; Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
9	BZX584C4V7-02V	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=4.4...5.0\text{B}; Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
A	1SS400	ROHM	di	$V_{R1}>80\text{B}; I_R<225\text{mA}; V_F(I_F=100\text{mA})<1.2\text{B}; I_S<0.1\text{mA}; I_{TSM}<4\text{Hc}$	SOD-523, SC-79	К*А
A	BAB92-02L	INF	dtv	$V_R<35\text{B}; I_F<10\text{mA}; V_F(I_F=100\text{mA})<1.0\text{B}; I_S<0.02\text{mA}$	SOD-523, SC-79	К*А
A	JDV2506S	TOSH	var	$V_R<10\text{B}; I_S<0.003\text{mA}; C_{1B}=15...17\text{нФ}; C_{4B}=7.0...8.5$	SOD-623	К*А
A, 4	1SS400	WEIT	di	$V_R<80\text{B}; I_R<100\text{mA}; V_F(I_F=100\text{mA})<1.2\text{B}; I_S<0.1\text{mA}; I_{TSM}<4\text{Hc}$	SOD-523, SC-79	К*А
A1	BB208-02	PHIL	var	$V_R>10\text{B}; I_S(V_R=10\text{B})<0.01\text{mA}; C_{1B}=19.9...23.2\text{нФ}; C_{7.5B}=4.5...5.4\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
A2	BB184	PHIL	var	$V_R>13\text{B}; I_S(V_R=10\text{B})<0.01\text{mA}; C_{1B}=12.7...15.3\text{нФ}; C_{10B}=1.87...2.13\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
A6	BAS16-02W	INF	di	$V_R<80\text{B}; I_R<200\text{mA}; V_F(I_F=150\text{mA})<1.25\text{B}; I_S<50\text{mA}$	SCD-80	К*А
AA	BAB92	INF	dtv	$V_R<35\text{B}; I_F<10\text{mA}; V_F(I_F=100\text{mA})<1.0\text{B}; I_S<0.02\text{mA}$	SCD-80	К*А
B	BB555	INF	var	$V_R<30\text{B}; I_S<20\text{mA}; I_R<0.01\text{mA}; C_{1B}=17.5...20\text{нФ}; C_{1B}/C_{28B}=8.2...9.8$	SCD-80	К*А
B	JDV2509S	TOSH	var	$V_R<10\text{B}; I_S<0.003\text{mA}; C_{1B}=9.7...11.1\text{нФ}; C_{4B}=4.45...5.45$	SOD-623	К*А
BB	BB555-02V	INF	var	$V_R<30\text{B}; I_F<20\text{mA}; I_R<0.01\text{mA}; C_{1B}=17.5...20\text{нФ}; C_{1B}/C_{28B}=8.2...9.8$	SOD-523, SC-79	К*А
C	BB179B	PHIL	var	$V_R<32\text{B}; I_S(V_R=30\text{B})<0.01\text{mA}; C_{1B}=18.22...20\text{нФ}; C_{28B}=1.9...2.25\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
C	BB565-02V	INF	var	$V_R<30\text{B}; I_S<20\text{mA}; I_R<0.01\text{mA}; C_{1B}=18.5...21.5\text{нФ}; C_{1B}/C_{28B}=9...11$	SOD-523, SC-79	К*А
C	JDV2508S	TOSH	var	$V_R<10\text{B}; I_S<0.003\text{mA}; C_{1B}=17.3...19.3\text{нФ}; C_{4B}=5.3...6.6$	SOD-623	К*А
C0	BZX585-B5V6	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=5.49...5.71\text{B}; Z_{T1}<40\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
C1	1SS387	TOSH	di	$V_R<80\text{B}; I_R<200\text{mA}; V_F(I_F=100\text{mA})<1.2\text{B}; I_S<0.5\text{mA}; I_{TSM}<4\text{Hc}$	SOD-523, SC-79	К*А
C1	BZX585-B2V4	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=2.35...2.45\text{B}; Z_{T1}<100\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
C2	BZX585-B2V7	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=2.65...2.75\text{B}; Z_{T1}<100\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
C3	BZX585-B3V0	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=2.94...3.06\text{B}; Z_{T1}<95\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
C4	BZX585-B3V3	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=3.23...3.37\text{B}; Z_{T1}<95\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
C5	BZX585-B3V6	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=3.53...3.67\text{B}; Z_{T1}<90\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
C6	BZX585-B3V9	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=3.82...3.98\text{B}; Z_{T1}<90\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
C7	BZX585-B4V3	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=4.21...4.39\text{B}; Z_{T1}<90\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
C8	BZX585-B4V7	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=4.61...4.79\text{B}; Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
C9	BZX585-B5V1	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=5.0...5.2\text{B}; Z_{T1}<60\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
CC	BB659	INF	var	$V_R<30\text{B}; I_F<20\text{mA}; I_R<0.01\text{mA}; C_{1B}=18.5...21.5\text{нФ}; C_{1B}/C_{28B}=9...11$	SCD-80	К*А
D	JDV2507S	TOSH	var	$V_R<10\text{B}; I_S<0.003\text{mA}; C_{1B}=4.0...4.9\text{нФ}; C_{4B}=1.85...2.35$	SOD-623	К*А
D0	BZD27C3V6P	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=100\text{mA})=3.4...3.8\text{B}; Z_{T1}<8\text{Om}$	DO-219AB, SMF	К*А
D1	BZD27C3V9P	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=100\text{mA})=3.7...4.1\text{B}; Z_{T1}<8\text{Om}$	DO-219AB, SMF	К*А
D2	BZD27C4V3P	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=100\text{mA})=4...4.6\text{B}; Z_{T1}<7\text{Om}$	DO-219AB, SMF	К*А
D3	BZD27C4V7P	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=100\text{mA})=4.4...5\text{B}; Z_{T1}<7\text{Om}$	DO-219AB, SMF	К*А
D4	BZD27C5V1P	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=100\text{mA})=4.8...5.4\text{B}; Z_{T1}<6\text{Om}$	DO-219AB, SMF	К*А
D5	BZD27C5V6P	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=100\text{mA})=5.2...6\text{B}; Z_{T1}<4\text{Om}$	DO-219AB, SMF	К*А
D6	BZD27C6V2P	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=100\text{mA})=5.8...6.6\text{B}; Z_{T1}<3\text{Om}$	DO-219AB, SMF	К*А
D7	BZD27C6V8P	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=100\text{mA})=6.4...7.2\text{B}; Z_{T1}<3\text{Om}$	DO-219AB, SMF	К*А
D8	BZD27C7V5P	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=100\text{mA})=7...7.9\text{B}; Z_{T1}<2\text{Om}$	DO-219AB, SMF	К*А
D9	BZD27C8V2P	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=100\text{mA})=7.7...8.7\text{B}; Z_{T1}<2\text{Om}$	DO-219AB, SMF	К*А
DE	BB659	INF	var	$V_R<30\text{B}; I_F<20\text{mA}; I_R<0.01\text{mA}; C_{1B}=36...40\text{нФ}; C_{1B}/C_{28B}=14.7$	SCD-80	К*А
E	BB689-02V	INF	var	$V_R<30\text{B}; I_S<20\text{mA}; I_R<0.01\text{mA}; C_{1B}=51...61.5\text{нФ}; C_{28B}=2.5...2.9$	SOD-523, SC-79	К*А
E	JDV2513S	TOSH	var	$V_R<10\text{B}; I_S<0.003\text{mA}; C_{1B}=5.7...6.7\text{нФ}; C_{4B}=1.85...2.45$	SOD-623	К*А
E0	BZD27C3V1P	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=50\text{mA})=8.5...9.6\text{B}; Z_{T1}<4\text{Om}$	DO-219AB, SMF	К*А
E0	BZX585-B15	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=14.7...15.3\text{B}; Z_{T1}<15\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
E1	BZD27C10P	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=50\text{mA})=9.4...10.6\text{B}; Z_{T1}<4\text{Om}$	DO-219AB, SMF	К*А
E1	BZX585-B6V2	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=6.08...6.32\text{B}; Z_{T1}<10\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
E2	BZD27C11P	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=50\text{mA})=10.4...11.6\text{B}; Z_{T1}<7\text{Om}$	DO-219AB, SMF	К*А
E2	BZX585-B6V8	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=6.66...6.94\text{B}; Z_{T1}<10\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
E3	BZD27C12P	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=50\text{mA})=11.4...12.7\text{B}; Z_{T1}<7\text{Om}$	DO-219AB, SMF	К*А
E3	BZX585-B7V5	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=7.35...7.65\text{B}; Z_{T1}<10\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
E4	BZD27C13P	VISH	dz	$V_Z(I_{ZT}=50\text{mA})=12.4...14.1\text{B}; Z_{T1}<10\text{Om}$	DO-219AB, SMF	К*А
E4	BZX585-B8V2	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{mA})=8.04...8.36\text{B}; Z_{T1}<10\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А

**SOD623**
SOD723**SOD523**
SCD80**SOD219AB**
SMF

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1*2
E5	BZD27C15P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=50 \text{ mA}) = 13.8...15.6 \text{ B}; Z_{T1} < 10 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
E5	BZX585-B9V1	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5 \text{ mA}) = 8.92...9.28 \text{ B}; Z_{T1} < 10 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
E6	BZD27C16P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=25 \text{ mA}) = 15.3...17.1 \text{ B}; Z_{T1} < 15 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
E6	BZX585-B10	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5 \text{ mA}) = 9.8...10.2 \text{ B}; Z_{T1} < 10 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
E7	BZD27C18P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=25 \text{ mA}) = 16.8...19.1 \text{ B}; Z_{T1} < 15 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
E7	BZX585-B11	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5 \text{ mA}) = 10.8...11.2 \text{ B}; Z_{T1} < 10 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
E8	BZD27C20P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=25 \text{ mA}) = 18.8...21.2 \text{ B}; Z_{T1} < 15 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
E8	BZX585-B12	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5 \text{ mA}) = 11.8...12.2 \text{ B}; Z_{T1} < 10 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
E9	BZD27C22P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=25 \text{ mA}) = 20.8...23.3 \text{ B}; Z_{T1} < 15 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
E9	BZX585-B13	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5 \text{ mA}) = 12.7...13.3 \text{ B}; Z_{T1} < 10 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
EE	BB689	INF	var	$V_R < 30 \text{ B}; I_R < 20 \text{ mA}; I_S < 0.01 \text{ mA}; C_{1B} = 51...61.5 \text{ нФ}; C_{2B} = 2.5...2.9$	SCD-80	К*А
F	BAS20-02W	SIEM	di	$V_F < 150 \text{ B}; I_F < 200 \text{ mA}; V_F (I_F = 100 \text{ mA}) < 1.0 \text{ B}; I_S < 0.1 \text{ mA}; C_0 < 5.0 \text{ нФ}; t_{\text{пер}} < 50 \text{ нс}$	SCD-80	К*А
F	BBY65-02V	INF	var	$V_R < 15 \text{ B}; I_R < 50 \text{ mA}; I_S < 0.01 \text{ mA}; C_{1B} = 20.25 \text{ нФ}; C_{4.7V} = 2.6...2.8 \text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
F	JDV2510S	TOSH	var	$V_R < 10 \text{ B}; I_R < 0.003 \text{ mA}; C_{0.5B} = 7.3...8.4 \text{ нФ}; C_{2.5B} = 2.75...3.4$	SOD-623	К*А
F0	BZD27C24P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=25 \text{ mA}) = 22.8...25.6 \text{ B}; Z_{T1} < 15 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
F0	BZX585-C5V6	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5 \text{ mA}) = 5.32...5.88 \text{ B}; Z_{T1} < 40 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
F0	CMOZ5V6	CSI	dz	$V_Z = 5.6 \text{ B (5%)}; P_0 < 350 \text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
F1	BZD27C27P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=25 \text{ mA}) = 25.1...28.9 \text{ B}; Z_{T1} < 15 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
F1	BZX585-C2V4	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5 \text{ mA}) = 2.28...2.52 \text{ B}; Z_{T1} < 100 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
F1	CMOZ2V4	CSI	dz	$V_Z = 2.4 \text{ B (5%)}; P_0 < 350 \text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
F1A	CMOZ2V6	CSI	dz	$V_Z = 2.6 \text{ B (5%)}; P_0 < 350 \text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
F2	BZD27C30P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=25 \text{ mA}) = 28...32 \text{ B}; Z_{T1} < 15 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
F2	BZX585-C2V7	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5 \text{ mA}) = 2.57...2.84 \text{ B}; Z_{T1} < 100 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
F2	CMOZ2V7	CSI	dz	$V_Z = 2.7 \text{ B (5%)}; P_0 < 350 \text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
F3	BZD27C33P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=25 \text{ mA}) = 31...35 \text{ B}; Z_{T1} < 15 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
F3	BZX585-C3V0	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5 \text{ mA}) = 2.85...3.15 \text{ B}; Z_{T1} < 95 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
F3	CMOZ3V0	CSI	dz	$V_Z = 3.0 \text{ B (5%)}; P_0 < 350 \text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
F4	BZD27C36P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=10 \text{ mA}) = 34...38 \text{ B}; Z_{T1} < 40 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
F4	BZX585-C3V3	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5 \text{ mA}) = 3.14...3.47 \text{ B}; Z_{T1} < 95 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
F4	CMOZ3V3	CSI	dz	$V_Z = 3.3 \text{ B (5%)}; P_0 < 350 \text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
F5	BZD27C39P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=10 \text{ mA}) = 37...41 \text{ B}; Z_{T1} < 40 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
F5	BZX585-C3V6	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5 \text{ mA}) = 3.42...3.78 \text{ B}; Z_{T1} < 90 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
F5	CMOZ3V6	CSI	dz	$V_Z = 3.6 \text{ B (5%)}; P_0 < 350 \text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
F6	BZD27C43P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=10 \text{ mA}) = 40...46 \text{ B}; Z_{T1} < 45 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
F6	BZX585-C3V9	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5 \text{ mA}) = 3.71...4.10 \text{ B}; Z_{T1} < 90 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
F6	CMOZ3V9	CSI	dz	$V_Z = 3.9 \text{ B (5%)}; P_0 < 350 \text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
F7	BZD27C47P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=10 \text{ mA}) = 44...50 \text{ B}; Z_{T1} < 45 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
F7	BZX585-C4V3	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5 \text{ mA}) = 4.09...4.52 \text{ B}; Z_{T1} < 90 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
F7	CMOZ4V3	CSI	dz	$V_Z = 4.3 \text{ B (5%)}; P_0 < 350 \text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
F8	BZD27C51P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=10 \text{ mA}) = 48...54 \text{ B}; Z_{T1} < 60 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
F8	BZX585-C4V7	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5 \text{ mA}) = 4.47...4.94 \text{ B}; Z_{T1} < 80 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
F8	CMOZ4V7	CSI	dz	$V_Z = 4.7 \text{ B (5%)}; P_0 < 350 \text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
F9	BZD27C56P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=10 \text{ mA}) = 52...60 \text{ B}; Z_{T1} < 60 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
F9	BZX585-C5V1	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5 \text{ mA}) = 4.85...5.36 \text{ B}; Z_{T1} < 60 \text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
F9	CMOZ5V1	CSI	dz	$V_Z = 5.1 \text{ B (5%)}; P_0 < 350 \text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
FA	JDV2S01E	TOSH	var	$V_R < 10 \text{ B}; I_R < 0.003 \text{ mA}; C_{1B} = 2.85...3.45 \text{ нФ}; C_{4B} = 1.35...1.81$	SOD-523, SC-79	К*А
FA	JDV2S02E	TOSH	var	$V_R < 10 \text{ B}; I_R < 0.003 \text{ mA}; C_{1B} = 1.8...2.3 \text{ нФ}; C_{4B} = 0.83...1.23$	SOD-523, SC-79	К*А
FE	JDV2S05E	TOSH	var	$V_R < 10 \text{ B}; I_R < 0.003 \text{ mA}; C_{1B} = 3.85...4.55 \text{ нФ}; C_{4B} = 1.94...2.48$	SOD-523, SC-79	К*А
FH	JDV2S14E	TOSH	var	$V_R < 10 \text{ B}; I_R < 0.003 \text{ mA}; C_{1B} = 44...49.5 \text{ нФ}; C_{4B} = 9.2...12$	SOD-523, SC-79	К*А
GH	BAR63-02V	INF	pin	$V_R < 50 \text{ B}; I_R < 100 \text{ mA}; V_F (I_F = 100 \text{ mA}) < 1.2 \text{ B}; I_S < 0.01 \text{ mA}$	SOD-523, SC-79	К*А
G	JDV2S01S	TOSH	var	$V_R < 10 \text{ B}; I_R < 0.003 \text{ mA}; C_{1B} = 2.85...3.45 \text{ нФ}; C_{4B} = 1.35...1.81$	SOD-623	К*А
Q0	BZD27C62P	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=10 \text{ mA}) = 58...66 \text{ B}; Z_{T1} < 80 \text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А

– SOD623
SOD723

– SOD523
SCD80

– SOD219AB
SMF



Код	Типонаминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1+2
G1	BZD27C68P	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=10\text{ mA})=64\dots72\text{ B}$; $Z_{T1}<80\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
G2	BZD27C75P	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=10\text{ mA})=70\dots79\text{ B}$; $Z_{T1}<100\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
G3	BZD27C82P	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=10\text{ mA})=77\dots87\text{ B}$; $Z_{T1}<100\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
G4	BZD27C91P	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=85\dots96\text{ B}$; $Z_{T1}<200\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
G5	BZD27C100P	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=94\dots106\text{ B}$; $Z_{T1}<200\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
G6	BZD27C110P	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=104\dots116\text{ B}$; $Z_{T1}<250\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
G7	BZD27C120P	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=114\dots127\text{ B}$; $Z_{T1}<250\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
G8	BZD27C130P	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=124\dots141\text{ B}$; $Z_{T1}<300\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
G9	BZD27C150P	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=138\dots156\text{ B}$; $Z_{T1}<300\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
GG	BAR63-02W	INF	pin	$V_R<50\text{ B}$; $I_F<100\text{ mA}$; $V_F(I_F=100\text{ mA})<1.2\text{ B}$; $I_H<0.01\text{ мкА}$	SCD-80	К*А
H	BB141	PHIL	var	$V_R>6\text{ B}$; $I_H(V_R=6\text{ B})<0.01\text{ мкА}$; $C_{1B}=3.9\dots4.5\text{ нФ}$; $C_{4B}=2.22\dots2.55\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
H	BB141	LRC	var	$V_R>6\text{ B}$; $I_H(V_R=6\text{ B})<0.01\text{ мкА}$; $C_{1B}=3.9\dots4.5\text{ нФ}$; $C_{4B}=2.22\dots2.55\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
H	BB659C-02V	INF	var	$V_R<30\text{ B}$; $I_F<20\text{ mA}$; $I_H<0.01\text{ мкА}$; $C_{1B}=36.5\dots42\text{ нФ}$; $C_{1B}/C_{2B\beta}=15.3$	SOD-523, SC-79	К*А
H	JDV2502S	TOSH	var	$V_R<10\text{ B}$; $I_H<0.003\text{ мкА}$; $C_{1B}=1.8\dots2.3\text{ нФ}$; $C_{4B}=0.83\dots1.23$	SOD-623	К*А
H0	BZD27C160P	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=153\dots171\text{ B}$; $Z_{T1}<350\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
H0	BZX585-C15	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=14.25\dots15.75\text{ B}$; $Z_{T1}<15\text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
H0	CMOZ15V	CSI	dz	$V_2=15\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
H1	BZD27C180P	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=168\dots191\text{ B}$; $Z_{T1}<400\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
H1	BZX585-C6V2	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=5.89\dots6.51\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
H1	CMOZ6V2	CSI	dz	$V_2=6.2\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
H2	BZD27C200P	VISH	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=188\dots212\text{ B}$; $Z_{T1}<500\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
H2	BZX585-C6V8	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=6.46\dots7.14\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
H2	CMOZ6V8	CSI	dz	$V_2=6.8\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
H3	BZX585-C7V5	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=7.13\dots7.88\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
H3	CMOZ7V5	CSI	dz	$V_2=7.5\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
H4	BZX585-C8V2	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=7.79\dots8.61\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
H4	CMOZ8V2	CSI	dz	$V_2=8.2\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
H5	BZX585-C9V1	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=8.65\dots9.56\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
H5	CMOZ9V1	CSI	dz	$V_2=9.1\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
H6	BZX585-C10	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=9.5\dots10.5\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
H6	CMOZ10V	CSI	dz	$V_2=10\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
H7	BZX585-C11	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=10.45\dots11.55\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
H7	CMOZ11V	CSI	dz	$V_2=11\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
H8	BZX585-C12	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=11.4\dots12.6\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
H8	CMOZ12V	CSI	dz	$V_2=12\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
H9	BZX585-C13	PHIL	dz	$V_2(I_{ZT}=5\text{ mA})=12.35\dots13.65\text{ B}$; $Z_{T1}<10\text{ Ом}$	SOD-523, SC-79	К*А
H9	CMOZ13V	CSI	dz	$V_2=13\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
HH	BB659C	INF	var	$V_R<30\text{ B}$; $I_F<20\text{ mA}$; $I_H<0.01\text{ мкА}$; $C_{1B}=36.5\dots42\text{ нФ}$; $C_{1B}/C_{2B\beta}=15.3$	SCD-80	К*А
II	BBV51-02W	INF	var	$V_R<7\text{ B}$; $I_F<20\text{ mA}$; $I_H<0.01\text{ мкА}$; $C_{1B}=5.05\dots5.75\text{ нФ}$; $C_{4V}=2.5\dots3.7\text{ нФ}$	SCD-80	К*А
J0	CMOZ39V	CSI	dz	$V_2=39\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
J1	CMOZ16V	CSI	dz	$V_2=16\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
J2	CMOZ18V	CSI	dz	$V_2=18\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
J3	CMOZ20V	CSI	dz	$V_2=20\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
J4	CMOZ22V	CSI	dz	$V_2=22\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
J5	CMOZ24V	CSI	dz	$V_2=24\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
J6	CMOZ27V	CSI	dz	$V_2=27\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
J7	CMOZ30V	CSI	dz	$V_2=30\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
J8	CMOZ33V	CSI	dz	$V_2=33\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
J9	CMOZ36V	CSI	dz	$V_2=36\text{ B}$ (5%); $P_D<350\text{ мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
K	BB142	PHIL	var	$V_R>6\text{ B}$; $I_H(V_R=6\text{ B})<0.01\text{ мкА}$; $C_{1B}=4\dots4.9\text{ нФ}$; $C_{4B}=1.85\dots2.35\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
K	BB142	LRC	var	$V_R>6\text{ B}$; $I_H(V_R=6\text{ B})<0.01\text{ мкА}$; $C_{1B}=4\dots4.9\text{ нФ}$; $C_{4B}=1.85\dots2.35\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
K	BB679-02V	INF	var	$V_R<30\text{ B}$; $I_F<20\text{ mA}$; $I_H<0.01\text{ мкА}$; $C_{1B}=43.5\dots51.5\text{ нФ}$; $C_{2B\beta}=2.4\dots2.8$	SOD-523, SC-79	К*А



1 2

SOD623
SOD723

SOD523
SCD80

SOD219AB
SMF

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц1*2
K	BZX584C30-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=2\text{mA})=28...32\text{B}$; $Z_{T1}<80\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
K	JDV2S05S	TOSH	var	$V_R < 10\text{B}$; $I_R < 0.003\text{mA}$; $C_{1B}=3.85...4.55\text{нФ}$; $C_{4B}=1.94...2.48$	SOD-623	К*А
K1	CMOZ43V	CSI	dz	$V_Z=43\text{B}$ (5%); $P_D < 350\text{мВт}$	SOD-523, SC-79	К*А
K3	BB145C	PHIL	var	$V_R > 10\text{B}$; $I_R (V_R=15\text{B}) < 0.003\text{mA}$; $C_{1B}=6.4...7.2\text{нФ}$; $C_{4B}=2.55...2.85\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
KK	BBY52-02W	INF	var	$V_R < 7\text{B}$; $I_R < 20\text{mA}$; $I_S < 0.01\text{mA}$; $C_{1B}=1.4...2.2\text{нФ}$; $C_{4B}=0.85...1.45\text{нФ}$	SCD-80	К*А
L	BB143	PHIL	var	$V_R > 6\text{B}$; $I_R (V_R=6\text{B}) < 0.01\text{mA}$; $C_{1B}=4.75...5.75\text{нФ}$; $C_{4B}=2.05...2.55\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
L	BB143	LRC	var	$V_R > 6\text{B}$; $I_R (V_R=6\text{B}) < 0.01\text{mA}$; $C_{1B}=4.75...5.75\text{нФ}$; $C_{4B}=2.05...2.55\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
L	BBY53-02V	INF	var	$V_R > 6\text{B}$; $I_R < 20\text{mA}$; $I_S < 0.01\text{mA}$; $C_{1B}=4.8...5.8\text{нФ}$; $C_{5B}=1.85...3.1\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
L	BZX584C47-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=2\text{mA})=44...50\text{B}$; $Z_{T1}<170\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
L2	BB202	PHIL	var	$V_R > 6\text{B}$; $I_R (V_R=6\text{B}) < 0.01\text{mA}$; $C_{0.2V}=28.2...33.5\text{нФ}$; $C_{2.3V}=7.2...11.2\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
LL	BBY53-02W	INF	var	$V_R > 6\text{B}$; $I_R < 20\text{mA}$; $I_S < 0.01\text{mA}$; $C_{1B}=4.8...5.8\text{нФ}$; $C_{5B}=1.85...3.1\text{нФ}$	SCD-80	К*А
M	BAR64-02W	SIEM	pin	$V_R < 200\text{B}$; $I_R < 100\text{mA}$; $V_F (I_F=50\text{mA}) < 1.1\text{B}$; $C_D < 0.35\text{нФ}$	SCD-80	К*А
M	BZX584C51-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=2\text{mA})=48...54\text{B}$; $Z_{T1}<180\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
N	BAR65-02V	INF	pin	$V_R < 30\text{B}$; $I_R < 100\text{mA}$; $V_F (I_F=100\text{mA}) < 1.0\text{B}$; $C_D < 0.9\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
п	BAT15-02V	INF	shd	$V_R < 4\text{B}$; $I_R < 100\text{mA}$; $V_F (I_F=10\text{mA}) < 0.41\text{B}$; $C_D < 0.35\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
N	BB181	PHIL	var	$V_R > 30\text{B}$; $I_R (V_R=30\text{B}) < 0.01\text{mA}$; $C_{0.5B}=8...17\text{нФ}$; $C_{2B}=0.7...1.055\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
N	BB181	LRC	var	$V_R > 30\text{B}$; $I_R (V_R=30\text{B}) < 0.01\text{mA}$; $C_{0.5B}=8...17\text{нФ}$; $C_{2B}=0.7...1.055\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
O	BAR64-02V	INF	pin	$V_R < 150\text{B}$; $I_R < 100\text{mA}$; $V_F (I_F=50\text{mA}) < 1.1\text{B}$; $C_D < 0.35\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
P	BZX584C11-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=5\text{mA})=10.4...11.6\text{B}$; $Z_{T1}<20\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
P	BZX584C36-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=2\text{mA})=34...38\text{B}$; $Z_{T1}<90\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
R	BZX584C10-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=5\text{mA})=9.4...10.6\text{B}$; $Z_{T1}<20\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
R	BZX584C39-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=2\text{mA})=37...41\text{B}$; $Z_{T1}<130\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
RA	BA895	INF	pin	$V_R > 50\text{B}$; $I_R < 50\text{mA}$; $V_F (I_F=50\text{mA}) < 1.1\text{B}$; $I_S < 0.02\text{mA}$	SCD-80	К*А
RR	BBY59-02V	INF	var	$V_R < 15\text{B}$; $I_R < 50\text{mA}$; $I_S < 0.02\text{mA}$; $C_{1B}=26.6...29\text{нФ}$; $C_{4B}=6.1...7.8\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
S	BAR64-02	PHIL	pin	$V_R > 175\text{B}$; $I_R < 100\text{mA}$; $V_F (I_F=50\text{mA}) < 1.1\text{B}$; $I_S < 0.1\text{mA}$	SOD-523, SC-79	К*А
S	BZX584C43-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=2\text{mA})=40...46\text{B}$; $Z_{T1}<150\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
S	BZX584C9V1-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=5\text{mA})=8.5...9.6\text{B}$; $Z_{T1}<15\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
S3	1SS388	TOSH	shd	$V_R < 40\text{B}$; $V_F (I_F=50\text{mA}) < 0.6\text{B}$; $I_R (V_R=10\text{B}) < 5\text{mA}$; $C_1 < 25\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
S4	1SS389	TOSH	shd	$V_R < 10\text{B}$; $V_F (I_F=100\text{mA}) < 0.5\text{B}$; $I_R (V_R=10\text{B}) < 20\text{mA}$; $C_1 < 40\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
T	BAR67-02V	INF	pin	$V_R < 150\text{B}$; $I_R < 200\text{mA}$; $V_F (I_F=50\text{mA}) < 1.2\text{B}$; $C_D < 0.9\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
T	BAR67-02W	SIEM	pin	$V_R < 150\text{B}$; $I_R < 200\text{mA}$; $V_F (I_F=50\text{mA}) < 1.2\text{B}$; $C_D < 0.9\text{нФ}$	SCD-80	К*А
td	BAT64-02V	INF	shd	$V_R < 40\text{B}$; $I_R < 250\text{mA}$; $V_F (I_F=100\text{mA}) < 0.75\text{B}$; $I_S < 2\text{mA}$; $C_D < 6\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
T	BZX584C8V2-02V	VISH	dz	$V_Z (I_{ZT}=5\text{mA})=7.7...8.7\text{B}$; $Z_{T1}<15\text{Om}$	SOD-523, SC-79	К*А
T1	1SV278	TOSH	var	$V_R > 30\text{B}$; $I_R (V_R=28\text{B}) < 0.01\text{mA}$; $C_{2B}=14.16...16.25\text{нФ}$; $C_{25B}=2.11...2.43\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
T3	1SV309	TOSH	var	$V_R > 30\text{B}$; $I_R (V_R=28\text{B}) < 0.01\text{mA}$; $C_{2B}=3.31...4.55\text{нФ}$; $C_{25B}=0.61...0.77\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
T7	1SV286	TOSH	var	$V_R > 30\text{B}$; $I_R (V_R=28\text{B}) < 0.01\text{mA}$; $C_{2B}=14.5...16.1\text{нФ}$; $C_{25B}=1.56...1.86\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
T8	1SV279	TOSH	var	$V_R > 15\text{B}$; $I_R (V_R=15\text{B}) < 0.003\text{mA}$; $C_{2B}=14...16\text{нФ}$; $C_{10B}=5.5...6.5\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
TC	1SV280	TOSH	var	$V_R > 15\text{B}$; $I_R (V_R=15\text{B}) < 0.003\text{mA}$; $C_{2B}=3.8...4.7\text{нФ}$; $C_{10B}=1.5...2\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
TD	1SV282	TOSH	var	$V_R > 34\text{B}$; $I_R (V_R=32\text{B}) < 0.01\text{mA}$; $C_{2B}=33...38\text{нФ}$; $C_{25B}=2.6...3\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
TE	1SV283	TOSH	var	$V_R > 34\text{B}$; $I_R (V_R=32\text{B}) < 0.01\text{mA}$; $C_{2B}=29...34\text{нФ}$; $C_{25B}=2.5...2.9\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
TF	1SV281	TOSH	var	$V_R > 10\text{B}$; $I_R (V_R=10\text{B}) < 0.003\text{mA}$; $C_{1B}=15...17\text{нФ}$; $C_{4B}=7.3...8.7\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
TJ	1SV290	TOSH	var	$V_R > 30\text{B}$; $I_R (V_R=28\text{B}) < 0.01\text{mA}$; $C_{2B}=41...49.5\text{нФ}$; $C_{25B}=2.5...3.2\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
TK	1SV291	TOSH	var	$V_R > 30\text{B}$; $I_R (V_R=28\text{B}) < 0.01\text{mA}$; $C_{2B}=42...5.7\text{нФ}$; $C_{25B}=0.53...0.68\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
TL	1SV284	TOSH	var	$V_R > 10\text{B}$; $I_R (V_R=10\text{B}) < 0.003\text{mA}$; $C_{1B}=15...17\text{нФ}$; $C_{4B}=7.3...8.5\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
TO	1SV285	TOSH	var	$V_R > 10\text{B}$; $I_R (V_R=10\text{B}) < 0.003\text{mA}$; $C_{1B}=4...4.9\text{нФ}$; $C_{4B}=1.85...2.35\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
TT	1SV303	TOSH	var	$V_R > 30\text{B}$; $I_R (V_R=28\text{B}) < 0.01\text{mA}$; $C_{2B}=42...51\text{нФ}$; $C_{25B}=2.1...3.1\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
TV	1SV305	TOSH	var	$V_R > 10\text{B}$; $I_R (V_R=10\text{B}) < 0.003\text{mA}$; $C_{1B}=17.3...19.3\text{нФ}$; $C_{4B}=5.3...6.6\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
TX	1SV308	TOSH	pin	$V_R > 30\text{B}$; $I_R < 50\text{mA}$; $V_F (I_F=50\text{mA}) < 1\text{B}$; $I_S < 0.1\text{mA}$	SOD-523, SC-79	К*А
TY	1SS381	TOSH	di	$V_R < 30\text{B}$; $I_R < 100\text{mA}$; $V_F (I_F=2\text{mA}) < 0.85\text{B}$; $I_S < 0.1\text{mA}$	SOD-523, SC-79	К*А
U	BB145	PHIL	var	$V_R > 6\text{B}$; $I_R (V_R=6\text{B}) < 0.01\text{mA}$; $C_{1B}=6.4...7.4\text{нФ}$; $C_{4B}=2.75...3.25\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
U	BB145	LRC	var	$V_R > 6\text{B}$; $I_R (V_R=6\text{B}) < 0.01\text{mA}$; $C_{1B}=6.4...7.4\text{нФ}$; $C_{4B}=2.75...3.25\text{нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
V6	JDV2S10T	TOSH	var	$V_R < 10\text{B}$; $I_R < 0.003\text{mA}$; $C_{0.5B}=7.3...8.4\text{нФ}$; $C_{2.5B}=2.75...3.4$	SOD-523, SC-79	К*А

– SOD623
SOD723

– SOD523
SCD80

– SOD219AB
SMF



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц:1+2
V1	1SV311	TOSH	var	$V_R > 10\text{ В}; I_R (V_R = 10\text{ В}) < 0.003\text{ мкА}; C_{1Б} = 9.7...11.1\text{ нФ}; C_{4Б} = 4.45...5.45\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
V2	1SV329	TOSH	var	$V_R > 10\text{ В}; I_R (V_R = 10\text{ В}) < 0.003\text{ мкА}; C_{1Б} = 5.7...6.7\text{ нФ}; C_{4Б} = 1.85...2.45\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
V6	1SV314	TOSH	var	$V_R > 10\text{ В}; I_R (V_R = 10\text{ В}) < 0.003\text{ мкА}; C_{0.5Б} = 7.3...8.4\text{ нФ}; C_{2.5Б} = 2.75...3.4\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
V7	1SV323	TOSH	var	$V_R > 10\text{ В}; I_R (V_R = 10\text{ В}) < 0.003\text{ мкА}; C_{1Б} = 26.5...29.5\text{ нФ}; C_{4Б} = 6...7.1\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
V8	1SV325	TOSH	var	$V_R > 10\text{ В}; I_R (V_R = 10\text{ В}) < 0.003\text{ мкА}; C_{1Б} = 44...49.5\text{ нФ}; C_{4Б} = 9.2...12\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
V9	1SV331	TOSH	var	$V_R > 10\text{ В}; I_R (V_R = 10\text{ В}) < 0.003\text{ мкА}; C_{1Б} = 17...19\text{ нФ}; C_{4Б} = 4.25...5.43\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
W5	GZF3V6C	VISH	dz	$V_2 = 3.4...3.8\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 100\text{ мА}) < 8\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
W6	GZF3V9C	VISH	dz	$V_2 = 3.7...4.1\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 100\text{ мА}) < 8\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
W7	GZF4V3C	VISH	dz	$V_2 = 4.0...4.6\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 100\text{ мА}) < 7\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
W8	GZF4V7C	VISH	dz	$V_2 = 4.4...5.0\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 100\text{ мА}) < 7\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
W9	GZF5V1C	VISH	dz	$V_2 = 4.8...5.4\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 100\text{ мА}) < 6\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WA	GZF5V6C	VISH	dz	$V_2 = 5.2...6.0\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 100\text{ мА}) < 4\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WB	GZF6V2C	VISH	dz	$V_2 = 5.8...6.6\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 100\text{ мА}) < 3\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WC	GZF6V8C	VISH	dz	$V_2 = 6.4...7.2\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 100\text{ мА}) < 3\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WD	GZF7V5C	VISH	dz	$V_2 = 7.0...7.9\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 100\text{ мА}) < 2\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WE	GZF8V2C	VISH	dz	$V_2 = 7.7...8.7\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 100\text{ мА}) < 2\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WF	GZF9V1C	VISH	dz	$V_2 = 8.5...9.6\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 50\text{ мА}) < 4\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WG	GZF10C	VISH	dz	$V_2 = 9.4...10.6\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 50\text{ мА}) < 4\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WH	GZF11C	VISH	dz	$V_2 = 10.4...11.6\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 50\text{ мА}) < 7\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WI	GZF12C	VISH	dz	$V_2 = 11.4...12.7\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 50\text{ мА}) < 7\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WK	GZF13C	VISH	dz	$V_2 = 12.4...14.1\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 50\text{ мА}) < 10\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WL	GZF15C	VISH	dz	$V_2 = 13.8...15.6\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 50\text{ мА}) < 10\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WM	GZF16C	VISH	dz	$V_2 = 15.3...17.1\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 25\text{ мА}) < 15\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WN	GZF18C	VISH	dz	$V_2 = 16.8...19.1\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 25\text{ мА}) < 15\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WO	GZF20C	VISH	dz	$V_2 = 18.8...21.2\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 25\text{ мА}) < 15\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WP	GZF22C	VISH	dz	$V_2 = 20.8...23.3\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 25\text{ мА}) < 15\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WR	GZF24C	VISH	dz	$V_2 = 22.8...25.6\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 25\text{ мА}) < 15\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WS	GZF27C	VISH	dz	$V_2 = 25.1...28.9\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 25\text{ мА}) < 15\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WT	GZF30C	VISH	dz	$V_2 = 28...32\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 25\text{ мА}) < 15\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WU	GZF33C	VISH	dz	$V_2 = 31...35\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 25\text{ мА}) < 15\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WW	GZF36C	VISH	dz	$V_2 = 34...38\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 10\text{ мА}) < 40\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WX	GZF39C	VISH	dz	$V_2 = 37...41\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 10\text{ мА}) < 40\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WY	GZF43C	VISH	dz	$V_2 = 40...46\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 10\text{ мА}) < 45\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
WZ	GZF47C	VISH	dz	$V_2 = 44...50\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 10\text{ мА}) < 45\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
X	BB187	PHIL	var	$V_R > 32\text{ В}; I_R (V_R = 30\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{2Б} = 29.3...34.2\text{ нФ}; C_{25Б} = 2.57...2.92\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
X	BB187	LRC	var	$V_R > 32\text{ В}; I_R (V_R = 30\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{2Б} = 29.3...34.2\text{ нФ}; C_{25Б} = 2.57...2.92\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
X1	GZF51C	VISH	dz	$V_2 = 48...54\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 10\text{ мА}) < 60\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
X2	GZF56C	VISH	dz	$V_2 = 52...60\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 10\text{ мА}) < 60\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
X3	GZF62C	VISH	dz	$V_2 = 58...66\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 10\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
X4	GZF68C	VISH	dz	$V_2 = 64...72\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 10\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
X5	GZF75C	VISH	dz	$V_2 = 70...79\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 10\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
X6	GZF82C	VISH	dz	$V_2 = 77...87\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 10\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
X7	GZF91C	VISH	dz	$V_2 = 85...96\text{ В}; Z_{T1} (I_2 = 5\text{ мА}) < 200\text{ Ом}$	DO-219AB, SMF	К*А
Y	BAS52-02V	INF	std	$V_R > 45\text{ В}; I_R < 750\text{ мА}; V_f (I_f = 200\text{ мА}) < 0.6\text{ В}; I_R < 80\text{ мА}; C_0 < 10\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
Y	BB182B	PHIL	var	$V_R > 34\text{ В}; I_R (V_R = 32\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{2Б} = 47...53\text{ нФ}; C_{25Б} = 2.65...3\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
Y	BB182B	LRC	var	$V_R > 34\text{ В}; I_R (V_R = 32\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{2Б} = 47...53\text{ нФ}; C_{25Б} = 2.65...3\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
Z	BB145B	PHIL	var	$V_R > 6\text{ В}; I_R (V_R = 6\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{1Б} = 6.4...7.2\text{ нФ}; C_{4Б} = 2.55...2.95\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
Z	BB145B	LRC	var	$V_R > 6\text{ В}; I_R (V_R = 6\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{1Б} = 6.4...7.2\text{ нФ}; C_{4Б} = 2.55...2.95\text{ нФ}$	SOD-523, SC-79	К*А
Z1	BB145B-01	PHIL	var	$V_R > 6\text{ В}; I_R (V_R = 6\text{ В}) < 0.01\text{ мкА}; C_{1Б} = 6.4...7.2\text{ нФ}; C_{4Б} = 2.55...2.95\text{ нФ}$	SOD-723	К*А



SOT883, TSLP, μDFN

Код	Типономиниал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3...
62	BAT62-07L4	INF	shd x2	$V_B < 40\text{ В}; I_C < 20\text{ мА}; V_F (I_F = 2\text{ мА}) < 1\text{ В}; I_S < 10\text{ мкА}; C_D < 0.6\text{ нФ}$	TSLP-4	K1•K2•A2•A1
83	BAT68-02L	INF	shd	$V_B < 8\text{ В}; I_C < 130\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 0.5\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}; C_D < 1.0\text{ нФ}$	TSLP-2	K•A
58	BBY58-02L	INF	var	$V_B < 10\text{ В}; I_C < 20\text{ мА}; I_S < 0.01\text{ мкА}; C_{1B} = 17.5...19.3\text{ нФ}; C_{4B} = 5.5...6.6\text{ нФ}$	TSLP-2	K•A
65	BBY57-02L	INF	var	$V_B < 10\text{ В}; I_C < 20\text{ мА}; I_S < 0.01\text{ мкА}; C_{1B} = 16.5...18.6\text{ нФ}; C_{4B} = 3.5...5.5\text{ нФ}$	TSLP-2	K•A
6A	BAS16-07L4	INF	di x 2	$V_B < 80\text{ В}; I_C < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 150\text{ мА}) < 1.25\text{ В}; I_S < 50\text{ мкА}$	TSLP-4	K1•K2•A2•A1
A4	BAV70L3	INF	di x2	$V_B < 80\text{ В}; I_C < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 50\text{ мА}) < 1\text{ В}; I_S (V_B = 70\text{ В}) < 0.15\text{ мкА}; C_D < 1.5\text{ нФ}; t_{\text{тг}} < 4\text{ нс}$	TSLP-3	A1•A2•K1, K2
A6	BAS16-02L	INF	di	$V_B < 80\text{ В}; I_C < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 150\text{ мА}) < 1.25\text{ В}; I_S < 50\text{ мкА}$	TSLP-2	K•A
AA	BA892-02L	INF	dtv	$V_B < 35\text{ В}; I_C < 10\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; I_S < 0.02\text{ мкА}$	TSLP-2	K•A
AA	MAX4599ELT	MAX	asw	SPDT; $R_{ON} < 65\text{ Ом}; V_{DD} = 2.0...5.5\text{ В}$	μDFN-6	IN•V+•GND•NC•COM•NO
AB	MAX4594ELT	MAX	asw	SPST; $R_{ON} < 12\text{ Ом}; V_{DD} = 2.0...5.5\text{ В}$	μDFN-6	COM•NO•GND•IN•n.c.•V+
AC	MAX4595ELT	MAX	asw	SPST; $R_{ON} < 12\text{ Ом}; V_{DD} = 2.0...5.5\text{ В}$	μDFN-6	COM•NC•GND•IN•n.c.•V+
AD	MAX4596ELT	MAX	asw	SPST; $R_{ON} < 12\text{ Ом}; V_{DD} = 2.0...5.5\text{ В}$	μDFN-6	IN•COM•GND•NO•n.c.•V+
AE	MAX4597ELT	MAX	asw	SPST; $R_{ON} < 12\text{ Ом}; V_{DD} = 2.0...5.5\text{ В}$	μDFN-6	IN•COM•GND•NC•n.c.•V+
B8	BBY58-07L4	INF	var	$V_B < 10\text{ В}; I_C < 20\text{ мА}; I_S < 0.01\text{ мкА}; C_{1B} = 17.5...19.3\text{ нФ}; C_{4B} = 5.5...6.6\text{ нФ}$	TSLP-4	K1•K2•A2•A1
D4	BC847AM	PHIL	nnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
D5	BC847BM	PHIL	nnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
D6	BC847CM	PHIL	nnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
DE	PDTA1147M	PHIL	Drnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 200; R_1 10\text{ кОм}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
DF	PDTA114YM	PHIL	Drnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 100; 10\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
DH	PDTA124EM	PHIL	Drnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 60; 22\text{ кОм}/22\text{ кОм}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
DL	PDTA143EM	PHIL	Drnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 30; 4.7\text{ кОм}/4.7\text{ кОм}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
DN	PDTA143XM	PHIL	Drnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 50; 4.7\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
DP	PDTA143ZM	PHIL	Drnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 100; 4.7\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
DR	PDTA144EM	PHIL	Drnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 80; 47\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
DS	PDTC114EM	PHIL	Drnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 30; 10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
DT	PDTC1147M	PHIL	Drnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 200; R_1 10\text{ кОм}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
DU	PDTC114YM	PHIL	Drnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 100; 10\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
DX	PDTC143EM	PHIL	Drnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 60; 22\text{ кОм}/22\text{ кОм}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
E1	PDTC143EM	PHIL	Drnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 30; 4.7\text{ кОм}/4.7\text{ кОм}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
E2	PDTC143XM	PHIL	Drnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 50; 4.7\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
E3	PDTC143ZM	PHIL	Drnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 100; 4.7\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
E7	PDTC144EM	PHIL	Drnp	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 80; 47\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT-883, SC-101	B•E•C
F	BAS70-02L	INF	shd	$V_B < 70\text{ В}; I_C < 70\text{ мА}; V_F (I_F = 15\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; I_S < 0.1\text{ мкА}; C_D < 2.0\text{ нФ}$	TSLP-2	K•A
FF	BAS40-02L	INF	shd	$V_B < 40\text{ В}; I_C < 120\text{ мА}; V_F (I_F = 40\text{ мА}) < 1\text{ В}; I_S < 1.0\text{ мкА}; C_D < 5\text{ нФ}$	TSLP-2	K•A
G	BAR63-02L	INF	pin	$V_B < 50\text{ В}; I_C < 100\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 1.2\text{ В}; I_S < 0.01\text{ мкА}$	TSLP-2	K•A
K	BBY51-02L	INF	var	$V_B < 7\text{ В}; I_C < 20\text{ мА}; I_S < 0.01\text{ мкА}; C_{1B} = 5.05...5.75\text{ нФ}; C_{4V} = 2.5...3.7\text{ нФ}$	TSLP-2	K•A
II	BBY52-02L	INF	var	$V_B < 7\text{ В}; I_C < 20\text{ мА}; I_S < 0.01\text{ мкА}; C_{1B} = 1.4...2.2\text{ нФ}; C_{4B} = 0.85...1.45\text{ нФ}$	TSLP-2	K•A
L	BAT62-02L	INF	shd	$V_B < 40\text{ В}; I_C < 20\text{ мА}; V_F (I_F = 2\text{ мА}) < 1\text{ В}; I_S < 10\text{ мкА}; C_D < 0.6\text{ нФ}$	TSLP-2	K•A
LO	RN1101FS	TOSH	Drnp	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 150\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T > 250\text{ МГц}; R_1/R_2 = 4.7/4.7\text{ кОм}$	SOT-823	B•E•C

μDFN-6



TSLP-4



TSLP-3, SOT883



TSLP-2



Код	Типономнал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3...
L1	RN1102FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T>250\text{ МГц}; R_1/R_2=10/10\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
L2	RN1103FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T>250\text{ МГц}; R_1/R_2=22/22\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
L3	RN1104FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T>250\text{ МГц}; R_1/R_2=47/47\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
L4	RN1105FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T>250\text{ МГц}; R_1/R_2=2.2/47\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
L5	RN1106FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T>250\text{ МГц}; R_1/R_2=4.7/47\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
L6	RN1107FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T>250\text{ МГц}; R_1/R_2=10/47\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
L7	RN1108FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T>250\text{ МГц}; R_1/R_2=22/47\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
L8	RN1109FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T>250\text{ МГц}; R_1/R_2=47/22\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
L9	RN1110FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T>250\text{ МГц}; R_1=4.7\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
LF	RN1111FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T>250\text{ МГц}; R_1=10\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
LH	RN1112FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T>250\text{ МГц}; R_1=22\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
LJ	RN1113FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T>250\text{ МГц}; R_1=47\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
LL	BBY53-02L	INF	var	$V_B=6\text{ В}; I_F<20\text{ мА}; I_R<0.01\text{ мА}; C_{1B}=4.8...5.8\text{ нФ}; C_{3B}=1.85...3.1\text{ нФ}$	TSLP-2	К*А
LL	BBY53-03L	INF	var	$V_B<6\text{ В}; I_F<20\text{ мА}; I_R<0.01\text{ мА}; C_{1B}=4.8...5.8\text{ нФ}; C_{3B}=1.85...3.1\text{ нФ}$	TSLP-3	А*п.с.*К
MM	BAR64-02L	INF	pin	$V_B<150\text{ В}; I_F<100\text{ мА}; V_F(I_F=50\text{ мА})<1.1\text{ В}; C_D<0.35\text{ нФ}$	TSLP-2	К*А
NN	BAR65-02L	INF	pin	$V_B<30\text{ В}; I_F<100\text{ мА}; V_F(I_F=100\text{ мА})<1.0\text{ В}; C_D<0.9\text{ нФ}$	TSLP-2	К*А
NP	BAT15-02L	INF	shd	$V_B<4\text{ В}; I_F<100\text{ мА}; V_F(I_F=10\text{ мА})<0.41\text{ В}; C_D<0.35\text{ нФ}$	TSLP-2	К*А
P3s	BAR63-07L4	INF	pin x2	$V_B=50\text{ В}; I_F<100\text{ мА}; V_F(I_F=100\text{ мА})<1.2\text{ В}; I_R<0.01\text{ мА}$	TSLP-4	К1*К2*А2*А1
U0	RN2101FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=50\text{ мВт}; R_1/R_2=4.7\text{ кОм}/4.7\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
U1	RN2102FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=50\text{ мВт}; R_1/R_2=10/10\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
U2	RN2103FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=50\text{ мВт}; R_1/R_2=22/22\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
U3	RN2104FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=50\text{ мВт}; R_1/R_2=47/47\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
U4	RN2105FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=50\text{ мВт}; R_1/R_2=2.2/47\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
U5	RN2106FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=50\text{ мВт}; R_1/R_2=4.7/47\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
U6	RN2107FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=50\text{ мВт}; R_1/R_2=10/47\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
U7	RN2108FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=50\text{ мВт}; R_1/R_2=22/47\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
U8	RN2109FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=50\text{ мВт}; R_1/R_2=47/22\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
U9	RN2110FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=50\text{ мВт}; R_1=4.7\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
UF	RN2111FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=50\text{ мВт}; R_1=10\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
UH	RN2112FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=50\text{ мВт}; R_1=22\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
UJ	RN2113FS	TOSH	Dnnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=50\text{ мВт}; R_1=47\text{ кОм}$	SOT-823	В*Е*С
WC	BCR133L3	INF	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; I_{B1}>30; f_T=130\text{ МГц}$	TSLP-3	В*Е*С
WD	BCR141L3	INF	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; I_{B1}>50; f_T>130\text{ МГц}$	TSLP-3	В*Е*С
WE	BCR148L3	INF	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=70\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; I_{B1}>70; f_T>100\text{ МГц}$	TSLP-3	В*Е*С
WH	BCR108L3	INF	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; I_{B1}>70; f_T>170\text{ МГц}$	TSLP-3	В*Е*С
WI	BCR158L3	INF	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=70\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; I_{B1}>70; f_T=100\text{ МГц}$	TSLP-3	В*Е*С
WJs	BCR135L3	INF	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; I_{B1}>70; f_T>150\text{ МГц}$	TSLP-3	В*Е*С
WM	BCR183L3	INF	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; I_{B1}>30;$	TSLP-3	В*Е*С
WP	BCR192L3	INF	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; I_{B1}>70; f_T>200\text{ МГц}$	TSLP-3	В*Е*С
WU	BCR162L3	INF	Dnnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; I_{B1}>20; f_T>200\text{ МГц}$	TSLP-3	В*Е*С



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TSM VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

SOT23-3, SOT323/523...

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
-28	PDAT114WU	PHIL	Dpnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 60; 47 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	В•Е•С
-20	PDTC114WU	PHIL	Dpnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 60; 47 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	В•Е•С
9	BC849	MOT	npn	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 200...800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
11	MMBD1501	NS	dl	$V_B < 180 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; C_D < 4 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	А•н.с. • К
11	MMBD1501	FAIR	dl	$V_B < 200 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; C_D < 4 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	А•н.с. • К
13	MMBD1503	NS	di-2	$V_B < 180 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; C_D < 4 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1 • K2 • K1, A2
13	MMBD1503	FAIR	di-2	$V_B < 200 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; C_D < 4 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1 • K2 • K1, A2
14	DTA114ECA	ROHM	Dpnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 30; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 10/10 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
14	MMBD1504	FAIR	di-2	$V_B < 200 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; C_D < 4 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1 • A2 • K1, K2
15	DTA124ECA	ROHM	Dpnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_{C(\text{max})} = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 56; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 22/22 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
15	MMBD1505	FAIR	di-2	$V_B < 200 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; C_D < 4 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K1 • K2 • A1, A2
22	MMBT4209	NS	npn	$V_{CB0} = 15 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 35; f_T = 850 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
23	MMBT3646	NS	npn	$V_{CB0} = 40 \text{ В}; I_C = 300 \text{ мА}; P_D = 625 \text{ мВт}; h_{21} > 15$	SOT23, SOD23	В•Е•С
24	DTC114ECA	ROHM	Dpnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 30; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 10/10 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
24	MMBD1201	FAIR	di	$V_B < 100 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_D < 2 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 3 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	А•н.с. • К
25	DTC124ECA	ROHM	Dpnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_{C(\text{max})} = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 56; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 22/22 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
29	MMBD1401	NS	d	$V_B < 175 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	А•н.с. • К
29	MMBD1401	NS	d	$V_B < 175 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	А•н.с. • К
31	MMBD1402	NS	d	$V_B < 175 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	н.с. • А • К
32	MMBD1403	NS	di-2	$V_B < 175 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1 • K2 • K1, A2
33	MMBD1404	NS	di-2	$V_B < 175 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1 • A2 • K1, K2
34	MMBD1405	NS	di-2	$V_B < 175 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K1 • K2 • A1, A2
43	DTA143EE	MOT	Dpnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 20; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 4.7/4.7 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	В•Е•С
45	BAS40-05	DIOT	shd-2	$V_B < 40 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 40 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.2 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1 • A2 • K2, K1
45	BAS40-05	MCS	shd-2	$V_B < 40 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 40 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.2 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1 • A2 • K2, K1
45	BAS40-05	TSC	shd-2	$V_B < 40 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 40 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.2 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1 • A2 • K2, K1
45	BAS40-05	GS	shd-2	$V_B < 40 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 40 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.2 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1 • A2 • K2, K1
46	BAS40-06	DIOT	shd-2	$V_B < 40 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 40 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.2 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	K1 • K2 • A1, A2
46	BAS40-06	MCS	shd-2	$V_B < 40 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 40 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.2 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	K1 • K2 • A1, A2
46	BAS40-06	TSC	shd-2	$V_B < 40 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 40 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.2 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	K1 • K2 • A1, A2
46	BAS40-06	GS	shd-2	$V_B < 40 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 40 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.2 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	K1 • K2 • A1, A2
69	DTA114YE	MOT	Dpnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 68; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 10/47 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	В•Е•С
69	DTC115EE	ROHM	Dpnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_{C(\text{max})} = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 82; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 100/100 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	В•Е•С
69	DTC115EUA	ROHM	Dpnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 82; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 100/100 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	В•Е•С
72	2N7002	SIL	nFET	$V_{DS} = 60 \text{ В}; I_D = 115 \text{ мА}; P_{D(\text{SSM})} = 1...2.5 \text{ Вт}; C_{\text{ISS}} < 50 \text{ пФ}$	SOT23, SOD23	G • S • D
73	MA4CS101A	M/A	shd	$V_B = 70 \text{ В}; I_C < 15 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 15 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	А•н.с. • К
74	MA4CS101B	M/A	shd-2	$V_B = 70 \text{ В}; I_C < 15 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 15 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1 • K2 • K1, A2
78	MMBT4258	FAIR	npn	$V_{CB0} = 12 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 225 \text{ мВт}; h_{21} > 30...120; f_T > 700 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
83	MA4CS102A	M/A	shd	$V_B = 8 \text{ В}; I_C < 30 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 10 \text{ мА}) < 500 \text{ мВ}; C_D < 1 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	А•н.с. • К
83	MMBT4400	FAIR	npn	$V_{CB0} = 60 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 50...150$	SOT23, SOD23	В•Е•С
84	MA4CS102B	M/A	shd-2	$V_B = 8 \text{ В}; I_C < 30 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 10 \text{ мА}) < 500 \text{ мВ}; C_D < 1 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1 • K2 • K1, A2
85	MA4CS102C	M/A	shd-2	$V_B = 8 \text{ В}; I_C < 30 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 10 \text{ мА}) < 500 \text{ мВ}; C_D < 1 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1 • A2 • K1, K2
85	MMBD1701	FAIR	dl	$V_B < 30 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 50 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; C_D < 1 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 0.7 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	А•н.с. • К
86	MMBD1702	FAIR	dl	$V_B < 30 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; V_{F1}(I_C = 50 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; C_D < 1 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 0.7 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	н.с. • А • К

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3
VMD3



SOT416
SOT523

SOT323
SOT346

SOT23-3
SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
87	MMBD1703	FAIR	dI-2	$V_{AK} < 30 В$; $I_F = 50 мА$; $V_{F(I_F=50 мА)} < 1.1 В$; $C_D < 1 нФ$; $t_{RR} < 0.7 нс$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
88	MMBD1704	FAIR	dI-2	$V_{AK} < 30 В$; $I_F = 50 мА$; $V_{F(I_F=50 мА)} < 1.1 В$; $C_D < 1 нФ$; $t_{RR} < 0.7 нс$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
89	MMBD1705	FAIR	dI-2	$V_{AK} < 30 В$; $I_F = 50 мА$; $V_{F(I_F=50 мА)} < 1.1 В$; $C_D < 1 нФ$; $t_{RR} < 0.7 нс$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
91	DTA1137KA	ROHM	DnpP	$V_{CEO} = 50 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 200 мВт$; $h_{21} > 33$; $f_T > 250 МГц$; $R_T, 1 к$	SOT346,SC59	B-E-C
95	DTA124TCA	ROHM	DnpP	$V_{CEO} = 50 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 150 мВт$; $h_{21} > 100...600$; $f_T > 250 МГц$; $R_T, 22 кОм$	SOT23,SOD23	B-E-C
101	PZM10NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 9.45...9.87 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 10 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
102	PZM10NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 9.77...10.21 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 10 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
103	PZM10NB3	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 10.11...10.55 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 10 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
111	PZM11NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 10.44...10.88 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 10 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
112	PZM11NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 10.76...11.22 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 10 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
113	PZM11NB3	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 11.10...11.56 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 10 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
121	PZM12NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 11.42...11.90 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 10 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
122	PZM12NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 11.74...12.24 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 10 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
123	PZM12NB3	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 12.08...12.60 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 10 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
131	PZM13NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 12.47...13.03 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 10 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
132	PZM13NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 12.91...13.49 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 10 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
133	PZM13NB3	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 13.37...13.96 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 10 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
142	DTA123JUA	ROHM	DnpP	$V_{CEO} = 50 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 200 мВт$; $h_{21} > 80$; $f_T > 250 МГц$; $R_T, P_D = 2,2/47 кОм$	SOT323,SC70	B-E-C
151	PZM15NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 13.84...14.46 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 15 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
152	PZM15NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 14.34...14.98 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 15 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
153	PZM15NB3	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 14.85...15.52 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 15 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
161	PZM16NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 15.37...16.01 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 20 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
162	PZM16NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 15.85...16.51 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 20 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
163	PZM16NB3	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 16.35...17.09 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 20 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
181	PZM18NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 16.94...17.70 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 20 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
182	PZM18NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 17.56...18.35 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 20 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
183	PZM18NB3	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 18.21...19.03 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 20 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
201	PZM20NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 18.86...19.70 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 20 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
202	PZM20NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 19.52...20.39 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 20 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
203	PZM20NB3	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 20.21...21.08 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 20 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
221	PZM22NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 20.88...21.77 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 25 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
222	PZM22NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 21.54...22.47 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 25 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
223	PZM22NB3	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 22.23...23.17 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 25 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
241	PZM24NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 22.93...23.96 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 30 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
242	PZM24NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 23.72...24.78 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 30 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
243	PZM24NB3	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 24.54...25.57 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 30 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
271	PZM2.7NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 2.5...2.75 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 100 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
272	PZM2.7NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 2.65...2.9 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 100 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
301	PZM3.0NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 2.8...3.05 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 95 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
302	PZM3.0NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 2.95...3.2 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 95 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
331	PZM3.3NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 3.1...3.35 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 95 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
332	PZM3.3NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 3.25...3.5 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 95 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
358	FDN358P	FAIR	DpMOS	$V_{DS} = 30 В$; $I_D = 1.5 А$; $P_D = 500 мВт$; $R_{DS(on)} = 0.125 Ом$	SOT23,SOD23	G-S-D
361	PZM3.6NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 3.4...3.65 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 90 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
362	PZM3.6NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 3.55...3.8 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 90 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
391	PZM3.9NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 3.7...3.97 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 90 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
392	PZM3.9NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 3.87...4.1 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 90 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
431	PZM4.3NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 4.01...4.21 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 90 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
432	PZM4.3NB2	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 4.15...4.34 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 90 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
433	PZM4.3NB3	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 4.28...4.48 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 90 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
471	PZM4.7NB1	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 мА)} = 4.42...4.61 В$; $Z_{T(I_Z=5 мА)} < 80 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
472	PZM4.7NB2	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 4.55...4.75 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 80 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
473	PZM4.7NB3	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 4.69...4.90 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 80 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
500	SSTPAD500	SIL	dl	V_{BE} : 55 В; I_C : < 10 мА; $V_{FE}(I_E=1\text{ mA})$: < 1.5 В; I_{ES} : < 500 нА; C_T : < 2 пФ	SOT23,SOD23	K-K-A
511	PZM5.1NB1	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 4.84...5.04 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 60 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
512	PZM5.1NB2	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 4.98...5.20 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 60 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
513	PZM5.1NB3	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 5.14...5.37 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 60 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
561	PZM5.6NB1	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 5.31...5.55 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 40 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
562	PZM5.6NB2	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 5.49...5.73 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 40 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
563	PZM5.6NB3	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 5.67...5.92 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 40 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
605	NDS0605	FAIR	pMOS	V_{DS} : 60 В; I_D : 180 мА; P_D : 360 мВт; $R_{\theta DS(on)}$: < 15 Ом	SOT23,SOD23	G-S-D
610	NDS0610	FAIR	pMOS	V_{DS} : 60 В; I_D : 120 мА; P_D : 360 мВт; $R_{\theta DS(on)}$: < 300 Ом	SOT23,SOD23	G-S-D
621	PZM6.2NB1	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 5.86...6.12 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 10 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
622	PZM6.2NB2	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 6.06...6.33 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 10 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
623	PZM6.2NB3	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 6.26...6.53 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 10 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
634	FMMT634	ZETEX	dnpn	V_{CE0} : 120 В; I_C : 900 мА; P_T : 625 мВт; f_T : > 140 МГц	SOT23,SOD23	B-E-C
681	PZM6.8NB1	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 6.47...6.73 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 15 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
682	PZM6.8NB2	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 6.86...7.14 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 15 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
683	PZM6.8NB3	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 6.65...6.93 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 15 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
701	2N7001	MOT	nFET	P_D : 250 мВт; $V_{DS(ON)}$: > 240 В; $R_{\theta DS(on)}$: 45 Ом	SOT23,SOD23	G-S-D
702	2N7002	ON	nFET	V_{DS} : 60 В; I_D : 115 мА; P_D : 300 мВт; $V_{GS(th)}$: 1...2.5 В; C_{ISS} : < 50 пФ	SOT23,SOD23	G-S-D
703	2N7003	MOT	nFET	V_{DS} : 500 В; I_D : 10 мА; P_D : 200 мВт; $R_{\theta DS(on)}$: < 300 Ом	SOT23,SOD23	G-S-D
712	NDS7002A	NS	nMOS	V_{DS} : 60 В; I_D : 0.28 А	SOT23,SOD23	G-S-D
751	PZM7.5NB1	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 7.06...7.36 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 10 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
752	PZM7.5NB2	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 7.28...7.60 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 10 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
753	PZM7.5NB3	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 7.52...7.84 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 10 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
821	PZM8.2NB1	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 7.76...8.10 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 10 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
822	PZM8.2NB2	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 8.02...8.36 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 10 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
823	PZM8.2NB3	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 8.28...8.64 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 10 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
852	S852T	VISH	npn	V_{CE0} : 12 В; I_C : 8 мА; P_D : 30 мВт; h_{FE1} : 40...150; f_T : 5.2 ГГц	SOT23,SOD23	B-E-C
911	PZM9.1NB1	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 8.56...8.93 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 10 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
912	PZM9.1NB2	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 8.85...9.23 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 10 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
913	PZM9.1NB3	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})$: 9.15...9.55 В; $Z_{TE}(I_{TE}=5\text{ mA})$ < 10 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
01	PDTA143EE	PHIL	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : > 30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT416,SC75A	B-E-C
01	PDTA143EK	PHIL	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : > 30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT346,SC59	B-E-C
010	SSTPAD10	SIL	dl	V_{BE} : 55 В; I_C : < 10 мА; $V_{FE}(I_E=1\text{ mA})$: < 1.5 В; I_{ES} : < 2 нА; C_T : < 2 пФ	SOT23,SOD23	K-K-A
011	SO2369R	STM	npn	V_{CE0} : 40 В; I_C : 200 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : 40...120; f_T : > 400 МГц	SOT23,SOD23	E-B-C
02	DTC123TKA	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 80; f_T : > 250 МГц; R_1/R_2 : 2.2/4.7 кОм	SOT346,SC59	B-E-C
02	PDTC143EE	PHIL	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : > 30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT416,SC75A	B-E-C
02	PDTC143EK	PHIL	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : > 30; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT346,SC59	B-E-C
020	SSTPAD20	SIL	dl	V_{BE} : 55 В; I_C : < 10 мА; $V_{FE}(I_E=1\text{ mA})$: < 1.5 В; I_{ES} : < 20 нА; C_T : < 2 пФ	SOT23,SOD23	K-K-A
028	SO3572R	SGS	npn	V_{CE0} : 15 В; P_D : 200 мВт; f_T : > 1 ГГц	SOT23,SOD23	E-B-C
02p	BST82	PHIL	nMOS	V_{DS} : 80 В; I_D : 175 мА; P_D : 300 мВт; $R_{\theta DS(on)}$: 7 Ом	SOT23,SOD23	G-S-D
03	DTC143TE	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 150 мВт; h_{FE1} : 100...600; f_T : > 250 МГц; R_1 : 4.7 кОм	SOT416,SC75A	B-E-C
03	DTC143TKA	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : 100...600; f_T : > 250 МГц; R_1 : 4.7 кОм	SOT346,SC59	B-E-C
03	DTC143TUA	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : 100...600; f_T : > 250 МГц; R_1 : 4.7 кОм	SOT323,SC70	B-E-C
03	PDTA144EE	PHIL	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 30; 10 кОм/10 кОм	SOT416,SC75A	B-E-C
03	PDTA144EF	PHIL	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 30; 10 кОм/10 кОм	SOT490,SC89	B-E-C
-03	PDTA144EU	PHIL	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 30; 10 кОм/10 кОм	SOT323,SC70	B-E-C
03W	SO2907AW	STM	npn	V_{CE0} : 60 В; I_C : 600 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : 100...300; f_T : > 200 МГц	SOT323,SC70	B-E-C

**SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3**

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
04	DTC114TE	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 100...600; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} > 10 \text{ К/Ом}$	SOT416, SC75A	B-E-C
04	DTC114TKA	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 100...600; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} > 10 \text{ К/Ом}$	SOT346, SC59	B-E-C
04	DTC114TUA	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 100...600; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} > 10 \text{ К/Ом}$	SOT323, SC70	B-E-C
04	PDTC114EK	PHIL	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 30; 10 \text{ К/Ом}/10 \text{ К/Ом}$	SOT346, SC59	B-E-C
-04	PMSS3904	PHIL	nprn	$V_{CE0} > 60 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
04	DTC114TCA	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 100...600; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} > 10 \text{ К/Ом}$	SOT23, SOD23	B-E-C
044	SO3571R	SGS	nprn	$V_{CE0} > 15 \text{ В}; P_D < 200 \text{ мВт}; f_T > 1.2 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	E-B-C
047	SO3570R	SGS	nprn	$V_{CE0} > 15 \text{ В}; P_D < 200 \text{ мВт}; f_T > 1.5 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	E-B-C
05	DTC124TE	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 100...600; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} < 22 \text{ К/Ом}$	SOT416, SC75A	B-E-C
05	DTC124TKA	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 100...600; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} < 22 \text{ К/Ом}$	SOT346, SC59	B-E-C
05	DTC124TUA	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 100...600; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} < 22 \text{ К/Ом}$	SOT323, SOD23	B-E-C
05	PDTA124EE	PHIL	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 60; 22 \text{ К/Ом}/22 \text{ К/Ом}$	SOT416, SC75A	B-E-C
05	PDTA124EK	PHIL	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 60; 22 \text{ К/Ом}/22 \text{ К/Ом}$	SOT346, SC59	B-E-C
05	SSTPAD5	SIL	dl	$V_R < 55 \text{ В}; I_R < 10 \text{ мА}; V_{\theta 1}(I_R = 1 \text{ мА}) < 1.5 \text{ В}; I_{\theta 1} < 5 \text{ нА}; C_T < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K-K-A
050	SSTPAD50	SIL	dl	$V_R < 55 \text{ В}; I_R < 10 \text{ мА}; V_{\theta 1}(I_R = 1 \text{ мА}) < 1.5 \text{ В}; I_{\theta 1} < 50 \text{ нА}; C_T < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K-K-A
06	DTC144TE	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 100...600; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} < 47 \text{ К/Ом}$	SOT416, SC75A	B-E-C
06	DTC144TKA	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 100...600; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} < 47 \text{ К/Ом}$	SOT346, SC59	B-E-C
06	DTC144TUA	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 100...600; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} < 47 \text{ К/Ом}$	SOT323, SC70	B-E-C
06	PDTC124EE	PHIL	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 60; 22 \text{ К/Ом}/22 \text{ К/Ом}$	SOT416, SC75A	E-B-C
06	PDTC124EK	PHIL	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 60; 22 \text{ К/Ом}/22 \text{ К/Ом}$	SOT346, SC59	B-E-C
07	PDTA144EE	PHIL	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 47 \text{ К/Ом}/47 \text{ К/Ом}$	SOT416, SC75A	B-E-C
07	PDTA144EEF	PHIL	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 47 \text{ К/Ом}/47 \text{ К/Ом}$	SOT490, SC89	B-E-C
07	PDTA144EK	PHIL	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 47 \text{ К/Ом}/47 \text{ К/Ом}$	SOT346, SC59	B-E-C
08	PDTC144EE	PHIL	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 47 \text{ К/Ом}/47 \text{ К/Ом}$	SOT416, SC75A	B-E-C
08	PDTC144EEF	PHIL	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 47 \text{ К/Ом}/47 \text{ К/Ом}$	SOT490, SC89	B-E-C
08	PDTC144EK	PHIL	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 47 \text{ К/Ом}/47 \text{ К/Ом}$	SOT346, SC59	B-E-C
081	SO2369AR	SGS	nprn	$V_{CE0} > 40 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 40...120; f_T > 500 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	E-B-C
09	DTC115TH	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 100...600; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} > 100 \text{ К/Ом}$	SOT416, SC75A	B-E-C
09	DTC115TKA	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 100...600; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} > 100 \text{ К/Ом}$	SOT346, SC59	B-E-C
09	DTC115TUA	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 100...600; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} > 100 \text{ К/Ом}$	SOT323, SC70	B-E-C
09	PDTC114EE	PHIL	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 30; 10 \text{ К/Ом}/10 \text{ К/Ом}$	SOT416, SC75A	B-E-C
09	PDTC114EEF	PHIL	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 30; 10 \text{ К/Ом}/10 \text{ К/Ом}$	SOT490, SC89	B-E-C
0A	DTC125TKA	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 100...600; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} > 200 \text{ К/Ом}$	SOT346, SC59	B-E-C
0A	DTC125TUA	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 100...600; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} > 200 \text{ К/Ом}$	SOT323, SC70	B-E-C
10	MRF9411LT1	MOT	nprn	$V_{CE0} > 20 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50...200; f_T > 8 \text{ ГГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
100	SSTPAD100	SIL	dl	$V_R < 55 \text{ В}; I_R < 10 \text{ мА}; V_{\theta 1}(I_R = 1 \text{ мА}) < 1.5 \text{ В}; I_{\theta 1} < 100 \text{ нА}; C_T < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K-K-A
10A	MMBZ10VAL	ON	dz-2	$V_{\theta 1}(I_{ZT} = 1 \text{ мА}) < 9.5...10.5 \text{ В}; V_{\theta 1}(I_{ZT} = 10 \text{ мА}) < 0.9 \text{ В}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1-A2
10A	PZM10NB2A	PHIL	dz-2	$V_{\theta 1}(I_{ZT} = 5 \text{ мА}) < 9.77...10.21 \text{ В}; Z_{T1}(I_{ZT} = 5 \text{ мА}) < 10 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	K1-K2-A1-A2
10X	PZM10NB	PHIL	dz	$V_{\theta 1}(I_{ZT} = 5 \text{ мА}) < 9.45...10.55 \text{ В}; Z_{T1}(I_{ZT} = 5 \text{ мА}) < 10 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
10V	Q2C210	TOSH	dz	$V_{\theta 1}(I_{ZT} = 5 \text{ мА}) < 9.40...10.60 \text{ В}; I_{\theta 1}(V_R = 8.0 \text{ В}) < 0.5 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_{ZT} = 0.5 \text{ мА}) < 120 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
11	MRF9511LT1	MOT	nprn	$V_{CE0} > 20 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 322 \text{ мВт}; h_{21} > 50...200; f_T > 8 \text{ ГГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
11	PDTA114TE	PHIL	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 200; R_{\theta 1} < 10 \text{ К/Ом}$	SOT416, SC75A	B-E-C
111	DTA1132UA	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 33; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} < 1/10 \text{ К/Ом}$	SOT323, SC70	B-E-C
113	DTA1432UA	ROHM	Dnpr	$V_{CE0} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 80; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} < 4,7/47 \text{ К/Ом}$	SOT323, SC70	B-E-C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
11A	PZM11NB2A	PHIL	dz-2	$V_{F1}(I_{F1}=5\text{ mA})$: 10.76...11.22 В; $Z_{T1}(I_{T1}=5\text{ mA}) < 10\text{ Ом}$	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
11V	PZM11NB	PHIL	dz	$V_{F1}(I_{F1}=5\text{ mA})$: 10.44...11.56 В; $Z_{T1}(I_{T1}=5\text{ mA}) < 10\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A•n.c.•K
11X	O2C211	TOSH	dz	$V_{F1}(I_{F1}=5\text{ mA})$: 10.40...11.60 В; $I_L(V_{F1}=8.5\text{ В}) < 0.5\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{T1}=0.5\text{ mA}) < 120\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A•n.c.•K
12	DTA123EE	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 150 мВт; $h_{FE} > 20$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 2.2/2.2 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
12	DTA123EKA	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; $h_{FE} > 20$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 2.2/2.2 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
12	DTA123EUA	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; $h_{FE} > 20$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 2.2/2.2 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
12	PDTC114YEF	PHIL	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; $h_{FE} > 100$; 10 кОм/47 кОм	SOT490,SC89	B•E•C
121	DTC113ZUA	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; $h_{FE} > 33$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 1/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
123	DTC143ZUA	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; $h_{FE} > 80$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 4.7/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
12A	MMBD1502A	NS		$V_B < 180\text{ В}$; $I_C < 600\text{ mA}$; $V_{F1}(I_C=200\text{ mA}) < 1.1\text{ В}$; $C_0 < 4\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	n.c.•A•K
12A	MMBZ10VAL	ON	dz-2	$V_{F1}(I_{F1}=1\text{ mA})$: 11.4...12.6 В; $V_{F1}(I_{F1}=10\text{ mA}) < 0.9\text{ В}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
12A	PZM12NB2A	PHIL	dz-2	$V_{F1}(I_{F1}=5\text{ mA})$: 11.74...12.24 В; $Z_{T1}(I_{T1}=5\text{ mA}) < 10\text{ Ом}$	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
12E	ZC2812E	ZETEX	shd-2	$V_B < 15\text{ В}$; $V_{F1}(I_C=1\text{ mA}) < 0.41\text{ В}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$; $C_0 < 1.2\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
12V	PZM12NB	PHIL	dz	$V_{F1}(I_{F1}=5\text{ mA})$: 11.42...12.60 В; $Z_{T1}(I_{T1}=5\text{ mA}) < 10\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A•n.c.•K
12X	O2C212	TOSH	dz	$V_{F1}(I_{F1}=5\text{ mA})$: 11.40...12.60 В; $I_L(V_{F1}=9.0\text{ В}) < 0.5\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{T1}=0.5\text{ mA}) < 110\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A•n.c.•K
13	BAS125	SIEM	shd	$V_B < 25\text{ В}$; $I_C < 100\text{ mA}$; $V_{F1}(I_C=35\text{ mA}) < 0.9\text{ В}$; $I_S < 1.0\text{ мкА}$; $C_0 < 1.1\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
13	DTA143ECA	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 150 мВт; $h_{FE} > 20$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 4.7/4.7 кОм	SOT23,SOD23	B•E•C
13	DTA143EE	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 150 мВт; $h_{FE} > 20$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 4.7/4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
13	DTA143EKA	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; $h_{FE} > 20$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 4.7/4.7 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
13	DTA143EUA	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; $h_{FE} > 20$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 4.7/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
13	MA4CS103A	M/A	shd	$V_B > 20\text{ В}$; $I_C < 100\text{ mA}$; $V_{F1}(I_C=35\text{ mA}) < 1\text{ В}$; $C_0 < 1.2\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
132	DTA123JE	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 150 мВт; $h_{FE} > 80$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 2.2/4.7 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
132	DTA123JUA	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; $h_{FE} > 80$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 2.2/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
13A	PZM13NB2A	PHIL	dz-2	$V_{F1}(I_{F1}=5\text{ mA})$: 12.91...13.49 В; $Z_{T1}(I_{T1}=5\text{ mA}) < 10\text{ Ом}$	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
13E	ZC2813E	ZETEX	shd-2	$V_B < 15\text{ В}$; $V_{F1}(I_C=1\text{ mA}) < 0.41\text{ В}$; $I_S < 0.1\text{ мкА}$; $C_0 < 1.2\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
13s	BAS125	INF	shd	$V_B < 25\text{ В}$; $I_C < 100\text{ mA}$; $V_{F1}(I_C=35\text{ mA}) < 0.9\text{ В}$; $I_S < 0.015\text{ мкА}$; $C_0 < 1.1\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
13s	BAS125W	SIEM	shd	$V_B < 25\text{ В}$; $I_C < 100\text{ mA}$; $V_{F1}(I_C=35\text{ mA}) < 0.9\text{ В}$; $I_S < 0.15\text{ мкА}$; $C_0 < 1.1\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A•n.c.•K
13V	PZM13NB	PHIL	dz	$V_{F1}(I_{F1}=5\text{ mA})$: 12.47...13.96 В; $Z_{T1}(I_{T1}=5\text{ mA}) < 10\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A•n.c.•K
13X	O2C213	TOSH	dz	$V_{F1}(I_{F1}=5\text{ mA})$: 12.40...14.10 В; $I_L(V_{F1}=10\text{ В}) < 0.5\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{T1}=0.5\text{ mA}) < 110\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A•n.c.•K
14	BAS125-04	SIEM	shd-2	$V_B < 25\text{ В}$; $I_C < 100\text{ mA}$; $V_{F1}(I_C=35\text{ mA}) < 0.9\text{ В}$; $I_S < 1.0\text{ мкА}$; $C_0 < 1.1\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
14	BAS125-04W	SIEM	shd-2	$V_B < 25\text{ В}$; $I_C < 100\text{ mA}$; $V_{F1}(I_C=35\text{ mA}) < 0.9\text{ В}$; $I_S < 0.15\text{ мкА}$; $C_0 < 1.1\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
14	DTA114EE	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 150 мВт; $h_{FE} > 30$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 10/10 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C
14	DTA114EKA	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; $h_{FE} > 30$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 10/10 кОм	SOT346,SC59	B•E•C
14	DTA114EUA	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 50 мА; P_D : 200 мВт; $h_{FE} > 30$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 10/10 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
14	MMBD1504	NS	di-2	$V_B < 180\text{ В}$; $I_C < 600\text{ mA}$; $V_{F1}(I_C=200\text{ mA}) < 1.1\text{ В}$; $C_0 < 4\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
142	DTC123JUA	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; $h_{FE} > 80$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 2.2/4.7 кОм	SOT323,SC70	B•E•C
14s	BAS125-04W	INF	shd-2	$V_B < 25\text{ В}$; $I_C < 100\text{ mA}$; $V_{F1}(I_C=35\text{ mA}) < 0.9\text{ В}$; $I_S < 0.015\text{ мкА}$; $C_0 < 1.1\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
14s	BAS125-04W	INF	shd-2	$V_B < 25\text{ В}$; $I_C < 100\text{ mA}$; $V_{F1}(I_C=35\text{ mA}) < 0.9\text{ В}$; $I_S < 0.015\text{ мкА}$; $C_0 < 1.1\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
15	BAS125-05	SIEM	shd-2	$V_B < 25\text{ В}$; $I_C < 100\text{ mA}$; $V_{F1}(I_C=35\text{ mA}) < 0.9\text{ В}$; $I_S < 1.0\text{ мкА}$; $C_0 < 1.1\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
15	BAS125-05W	SIEM	shd-2	$V_B < 25\text{ В}$; $I_C < 100\text{ mA}$; $V_{F1}(I_C=35\text{ mA}) < 0.9\text{ В}$; $I_S < 0.15\text{ мкА}$; $C_0 < 1.1\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
15	DTA124EE	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; $I_{C(max)}$: 100 мА; P_D : 150 мВт; $h_{FE} > 56$; $f_T > 250\text{ МГц}$; $R_{\theta 1/R_{\theta 2}}$: 2.2/2.2 кОм	SOT416,SC75A	B•E•C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346
SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
15	DTA124EKA	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 30 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 56; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta J}/R_{\theta C} > 22/22 \text{ К/К}$	SOT346, SC59	B•E•C
15	DTA124EUA	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 30 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 56; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta J}/R_{\theta C} > 22/22 \text{ К/К}$	SOT323, SC70	B•E•C
15	MMBD1505	NS	di-2	$V_{CE} > 180 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; V_{F(I_C=200 \text{ мА})} < 1.1 \text{ В}; C_D < 4 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
15	MMBT3960	MOT	npn	$V_{CEB} > 20 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}; h_{21} > 30 \dots 300$	SOT23, SOD23	B•E•C
156	DTA144VUA	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 33; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta J}/R_{\theta C} > 47/10 \text{ К/К}$	SOT323, SC70	B•E•C
15A	MMBZ15VAL	ON	dz-2	$V_{Z(I_Z=1 \text{ мА})} < 14.25 \dots 15.75 \text{ В}; V_{F(I_F=10 \text{ мА})} < 0.9 \text{ В}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
15A	PZM15NB2A	PHIL	dz-2	$V_{Z(I_Z=5 \text{ мА})} < 14.34 \dots 14.98 \text{ В}; Z_{T(I_Z=5 \text{ мА})} < 15 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	K1•K2•A1, A2
15s	BAS125-05	INF	shd-2	$V_{CE} > 25 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; V_{F(I_F=35 \text{ мА})} < 0.9 \text{ В}; I_S < 1.0 \text{ мкА}; C_D < 1.1 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
15s	BAS125-05W	INF	shd-2	$V_{CE} > 25 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; V_{F(I_F=35 \text{ мА})} < 0.9 \text{ В}; I_S < 1.0 \text{ мкА}; C_D < 1.1 \text{ нФ}$	SOT323, SC70	A1•A2•K2, K1
15V	PZM15NB	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 \text{ мА})} < 13.84 \dots 15.52 \text{ В}; Z_{T(I_Z=5 \text{ мА})} < 15 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A•n.c.•K
15X	Q2C215	TOSH	dz	$V_{Z(I_Z=5 \text{ мА})} < 13.80 \dots 15.60 \text{ В}; I_{(V_{Z=11 \text{ В}})} < 0.5 \text{ мА}; Z_{T(I_Z=0.5 \text{ мА})} < 110 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A•n.c.•K
16	BAS125-06W	SIEM	shd-2	$V_{CE} > 25 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; V_{F(I_F=35 \text{ мА})} < 0.9 \text{ В}; I_S < 0.15 \text{ мкА}; C_D < 1.1 \text{ нФ}$	SOT323, SC70	K1•K2•A1, A2
16	DTA144EE	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_{C(\text{max})} < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 68; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta J}/R_{\theta C} > 47/47 \text{ К/К}$	SOT416, SC75A	B•E•C
16	DTA144EKA	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 30 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 68; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta J}/R_{\theta C} > 47/47 \text{ К/К}$	SOT346, SC59	B•E•C
16	DTA144EUA	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_{C(\text{max})} < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 68; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta J}/R_{\theta C} > 47/47 \text{ К/К}$	SOT323, SC70	B•E•C
166	DTC144VUA	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 33; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta J}/R_{\theta C} > 47/10 \text{ К/К}$	SOT323, SC70	B•E•C
16s	BAS125-06	SIEM	shd-2	$V_{CE} > 25 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; V_{F(I_F=35 \text{ мА})} < 0.9 \text{ В}; I_S < 1.0 \text{ мкА}; C_D < 1.1 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
16s	BAS125-06W	INF	shd-2	$V_{CE} > 25 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; V_{F(I_F=35 \text{ мА})} < 0.9 \text{ В}; I_S < 1.0 \text{ мкА}; C_D < 1.1 \text{ нФ}$	SOT323, SC70	K1•K2•A1, A2
16V	PZM16NB	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 \text{ мА})} < 15.37 \dots 17.09 \text{ В}; Z_{T(I_Z=5 \text{ мА})} < 20 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A•n.c.•K
16X	Q2C216	TOSH	dz	$V_{Z(I_Z=5 \text{ мА})} < 15.30 \dots 17.10 \text{ В}; I_{(V_{Z=12 \text{ В}})} < 0.5 \text{ мА}; Z_{T(I_Z=0.5 \text{ мА})} < 150 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A•n.c.•K
179	DTA115UU	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 27; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
179	FMMT5179	ZETEX	npn	$V_{CEB} > 20 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 25 \dots 250; f_T > 1100 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B•E•C
18	PDTCT1432K	PHIL	Dnpnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 100; 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B•E•C
181	BFQ181	SIEM	npn	$V_{CEB} > 20 \text{ В}; I_C < 20 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	B•E•C
182	BFQ182	SIEM	npn	$V_{CEB} > 20 \text{ В}; I_C < 35 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 8 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
183	DTC1115U	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 27; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
18A	CMPZ5221B	CSI	dz	$V_{Z(I_Z=20 \text{ мА})} < 2.28 \dots 2.52 \text{ В}; I_{(V_{Z=1.0 \text{ В}})} < 100 \text{ мА}; Z_{T(I_Z=20 \text{ мА})} < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
18A	MMBZ18VAL	ON	dz-2	$V_{Z(I_Z=1 \text{ мА})} < 17.1 \dots 18.9 \text{ В}; V_{F(I_F=10 \text{ мА})} < 0.9 \text{ В}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
18A	MMBZ5221BLT1	ON	dz	$V_{Z(I_Z=20 \text{ мА})} < 2.28 \dots 2.52 \text{ В}; I_S < 100 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
18B	CMPZ5222B	CSI	dz	$V_{Z(I_Z=20 \text{ мА})} < 2.375 \dots 2.625 \text{ В}; I_{(V_{Z=1.0 \text{ В}})} < 100 \text{ мА}; Z_{T(I_Z=20 \text{ мА})} < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
18B	MMBZ5222BLT1	ON	dz	$V_{Z(I_Z=20 \text{ мА})} < 2.37 \dots 2.63 \text{ В}; I_S < 100 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
18C	CMPZ5223B	CSI	dz	$V_{Z(I_Z=20 \text{ мА})} < 2.565 \dots 2.835 \text{ В}; I_{(V_{Z=1.0 \text{ В}})} < 75 \text{ мкА}; Z_{T(I_Z=20 \text{ мА})} < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•n.c.~K
18C	MMBZ5223BLT1	ON	dz	$V_{Z(I_Z=20 \text{ мА})} < 2.57 \dots 2.84 \text{ В}; I_S < 75 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A•n.c.~K
18D	CMPZ5224B	CSI	dz	$V_{Z(I_Z=20 \text{ мА})} < 2.66 \dots 2.94 \text{ В}; I_{(V_{Z=1.0 \text{ В}})} < 75 \text{ мкА}; Z_{T(I_Z=20 \text{ мА})} < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•n.c.~K
18D	MMBZ5224BLT1	ON	dz	$V_{Z(I_Z=20 \text{ мА})} < 2.66 \dots 2.94 \text{ В}; I_S < 75 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A•n.c.~K
18E	CMPZ5225B	CSI	dz	$V_{Z(I_Z=20 \text{ мА})} < 2.85 \dots 3.15 \text{ В}; I_{(V_{Z=1.0 \text{ В}})} < 50 \text{ мкА}; Z_{T(I_Z=20 \text{ мА})} < 29 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•n.c.~K
18E	MMBZ5225B	VISH	dz	$V_{Z(I_Z=20 \text{ мА})} < 2.85 \dots 3.15 \text{ В}; I_S < 50 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A•n.c.~K
18E	MMBZ5225BLT1	ON	dz	$V_{Z(I_Z=20 \text{ мА})} < 2.85 \dots 3.15 \text{ В}; I_S < 50 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A•n.c.~K
18F	MMBZ5260B	VISH	dz	$V_{Z(I_Z=3 \text{ мА})} < 40.85 \dots 45.15 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A•n.c.~K
18V	PZM18NB	PHIL	dz	$V_{Z(I_Z=5 \text{ мА})} < 16.94 \dots 19.03 \text{ В}; Z_{T(I_Z=5 \text{ мА})} < 20 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A•n.c.~K
18X	Q2C218	TOSH	dz	$V_{Z(I_Z=5 \text{ мА})} < 16.80 \dots 19.10 \text{ В}; I_{(V_{Z=14 \text{ В}})} < 0.5 \text{ мА}; Z_{T(I_Z=0.5 \text{ мА})} < 150 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A•n.c.~K
19	DTA115EE	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_{C(\text{max})} < 100; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 82; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta J}/R_{\theta C} > 100/100 \text{ К/К}$	SOT416, SC75A	B•E•C
19	DTA115EKA	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 30; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 82; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta J}/R_{\theta C} > 100/100 \text{ К/К}$	SOT346, SC59	B•E•C
19	DTA115EUA	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 20 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 82; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta J}/R_{\theta C} > 100/100 \text{ К/К}$	SOT323, SC70	B•E•C
19	PDTA1432K	PHIL	Dnpnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 100; 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B•E•C
1A	BC846A	CDIL	npn	$V_{CEB} > 80 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 110 \dots 220; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
1A	BC846A	TOSH	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T = 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1A	BC846A	DIODS	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T = 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1A	BC846A	VISH	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 310$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1A	BC846AF	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T > 100$ МГц	SOT490, SC89	В•Е•С
1A	BC846ALT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1A	BC846AT	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T > 100$ МГц	SOT416, SC75A	В•Е•С
1A	BC846AWT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1A	BC846AWT1	LRC	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1A	BC846AWT1	ON	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1A	FMMT3904	MOT	npn	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 100...300$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1A	FMMT3904	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 100...300$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1A	IRLML2402	IR	nMOS	HEXFET; $V_{DS} = 20$ В; $I_D = 0.9$ А; $P_D = 540$ мВт; $R_{DS(on)} < 0.35$ Ом	SOT23, SOD23	G•S•D
1A	KST3904	SAMS	npn	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 100...300$; $f_T = 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1A	MMBT3904	VISH	npn	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 100...300$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1A	TMPT3904	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 100...300$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
-1A	PMST3904	PHIL	npn	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 100...300$; $f_T = 300$	SOT23, SC70	В•Е•С
1A-	BC846AW	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1AG	2SC3339GR	TOSH	npn	$V_{CE0} = 50$ В; $I_C = 150$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 200...400$; $f_T > 80$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1AL	2SC3339BL	TOSH	npn	$V_{CE0} = 50$ В; $I_C = 150$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 350...700$; $f_T > 80$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1AM	MMBT3904LT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} = 100...300$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1AO	2SC3339O	TOSH	npn	$V_{CE0} = 50$ В; $I_C = 150$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 70...140$; $f_T > 80$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Ap	BC846A	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1AQ	2SB779Q	PAN	pnip	$V_{CE0} = 25$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 90...155$; $f_T = 150$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1AR	2SB779R	PAN	pnip	$V_{CE0} = 25$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 130...220$; $f_T = 150$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1AR	BC846AR	PHIL	npn	$V_{CE0} = 65$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 310$ мВт; $h_{21} = 220$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	Е•В•С
1As	BC846A	INF	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T = 250$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1As	BC846AT	INF	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T = 250$ МГц	SOT416, SC75A	В•Е•С
1As	BC846AW	INF	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T = 250$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1At	BC846A	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1At	BC846AW	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 110...220$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1AY	2SC3339Y	TOSH	npn	$V_{CE0} = 50$ В; $I_C = 150$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 120...240$; $f_T > 80$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1B	BC846B	CDIL	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1B	BC846B	TOSH	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T = 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1B	BC846B	DIODS	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T = 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1B	BC846B	VISH	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 310$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1B	BC846B	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T = 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1B	BC846BF	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 100$ МГц	SOT490, SC89	В•Е•С
1B	BC846BLT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1B	BC846BT	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 100$ МГц	SOT416, SC75A	В•Е•С
1B	BC846BW1	LRC	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1B	BC846BWT1	ON	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1B	IRLML2803	IR	nMOS	HEXFET; $V_{DS} = 30$ В; $I_D = 0.9$ А; $P_D = 540$ мВт; $R_{DS(on)} < 0.4$ Ом	SOT23, SOD23	G•S•D
1B	KST2222	SAMS	npn	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 600$ мА; $P_D = 350$ мВт; $h_{21} > 75$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1B	TMPT2222	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 60$ В; $I_{CBO} < 10$ нА; $h_{21} = 100...300$; $V_{CE(sat)} < 0.4$ В; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
-1B	PMST2222	PHIL	npn	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 600$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 100...300$; $f_T = 250$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1B-	BC846BW	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1BG	2SC3340GR	TOSH	npn	$V_{CE0} = 120$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 200...400$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1BL	2SC3340BL	TOSH	npn	$V_{CE0} = 120$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 350...700$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Bp	BC846B	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1BR	BC846BR	PHIL	npn	$V_{CE0} = 65$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 310$ мВт; $h_{21} = 330$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	Е•В•С
1Bs	BC846B	SIEM	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T = 250$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Bs	BC846BT	INF	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T = 250$ МГц	SOT416, SC75A	В•Е•С

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3
VMD3



SOT416
SOT523

SOT323
SOT346

SOT23-3
SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
1B8	BC846BW	PHL	npn	$V_{CE0} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T = 250\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1B1	BC846B	PHL	npn	$V_{CE0} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T = 100\text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B•E•C
1B1	BC846BW	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T = 100\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1BZ	FMMT2222	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 60\text{ В}; I_C = 600\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 100...300; f_T = 250\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1C	FMMTA20	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 40\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 40...400; f_T = 125\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1C	IRLML302	IR	pMOS	HEXFET; $V_{GS} = 20\text{ В}; I_D = 0.62\text{ А}; P_D = 540\text{ мВт}; R_{DS(on)} < 0.9\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G•S•D
1C	KST20	SAMS	npn	$V_{CE0} = 40\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} = 40...400; f_T = 125\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1C	MMBTA20LT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 40\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 225\text{ мВт}; h_{21} = 40...400; f_T = 125\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1CL	2SC4082L	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 27...56; f_T = 1500\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1CM	2SC4082M	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 39...82; f_T = 1500\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1CN	2SC4082N	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 56...120; f_T = 1500\text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B•E•C
1CO	2SC3341O	TOSH	npn	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 70...140; f_T = 200\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1CP	2SC4082P	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 82...180; f_T = 1500\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1Cp	BAV50-05	PHIL	pin-2	$V_A = 50\text{ В}; I_C < 50\text{ мА}; V_{E(I=50\text{ мА})} < 1.1\text{ В}; I_{E(I=0.1\text{ мА})} < 1\text{ мА}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
1CQ	2SC4082Q	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 120...270; f_T = 1500\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1CY	2SC3341Y	TOSH	npn	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 120...240; f_T = 200\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1D	BC846	CDIL	npn	$V_{CE0} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 110...450; f_T = 100\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1D	IRLML5103	IR	pMOS	HEXFET; $V_{GS} = 30\text{ В}; I_D = 0.61\text{ А}; P_D = 540\text{ мВт}; R_{DS(on)} < 1\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G•S•D
1D	KST42	SAMS	npn	$V_{CE0} = 300\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} > 40; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1D	MBTA42	TOSH	npn	$V_{CE0} = 300\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 40; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1D	MMBTA42	VISH	npn	$V_{CE0} = 300\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} > 25; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1D	MMBTA42LT1	ON	npn	$V_{CE0} = 300\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 225\text{ мВт}; h_{21} > 25; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1D	SMBTA20	VISH	npn	$V_{CE0} = 40\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 40...400; f_T = 125\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1D	TMPTA42	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 300\text{ В}; I_{C(20)} < 100\text{ нА}; h_{21} > 40; V_{CE(sat)} < 0.5\text{ В}; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1D-	BC846W	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 110...450; f_T = 100\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1D-	BC846W	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 110...450; f_T = 100\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1DL	2SC4083L	ROHM	npn	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 27...56; f_T = 3200\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1DM	2SC4083M	ROHM	npn	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 39...82; f_T = 3200\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1DN	2SC4083N	ROHM	npn	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 56...120; f_T = 3200\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1DP	2SC4083P	ROHM	npn	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 82...180; f_T = 3200\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1Dp	BC846	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 110...450; f_T = 100\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1DQ	2SC4083Q	ROHM	npn	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 120...270; f_T = 3200\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1DR	2SD1328R	PAN	npn	$V_{CE0} = 25\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 200...350$	SOT346, SC59	B•E•C
1DR	MSD1328R	MOT	npn	$V_{CE0} = 25\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}$	SOT346, SC59	B•E•C
1DS	2SD1328S	PAN	npn	$V_{CE0} = 25\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 300...500$	SOT346, SC59	B•E•C
1D-	2SD1328T	PAN	npn	$V_{CE0} = 25\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 400...800$	SOT346, SC59	B•E•C
1Dt	BC846	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 110...450; f_T = 100\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1Dt	BC846W	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 110...450; f_T = 100\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1Dt	BC846W	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 110...450; f_T = 100\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1E	BC847A	CDIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T = 300\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1E	BC847A	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T = 300\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1E	BC847A	TOSH	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T = 300\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1E	BC847A	VISH	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 310\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T = 300\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1E	BC847AF	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT490, SC89	B•E•C
1E	BC847ALT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1E	BC847AT	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT416, SC75A	B•E•C
1E	BC847AT	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT523	B•E•C
1E	BC847AWT1	LRC	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1E	BC847AWT1	ON	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
1E	FMMTA43	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 200\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 50...200; f_T = 50\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
1E	IRLML6402	IR	pMOS	HEXFET; $V_{GS} = 20\text{ В}; I_D = 2.2\text{ А}; P_D = 1.3\text{ Вт}; R_{DS(on)} < 0.135\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G•S•D
1E	KST43	SAMS	npn	$V_{CE0} = 200\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} > 40; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типонаимал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3
1E	TMPT4A3	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 200\text{ В}; I_{CE0} < 100\text{ мА}; h_{21} > 40; V_{CEsat} < 0.5\text{ В}; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1E	BC847A	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT323.SC70	В·Е·С
1EL	2SC4084L	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_{CE} = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 27...56; f_T > 200\text{ МГц}$	SOT323.SC70	В·Е·С
TEM	2SC4084M	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_{CE} = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 39...82; f_T > 200\text{ МГц}$	SOT323.SC70	В·Е·С
1EN	2SC4084N	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_{CE} = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 56...120; f_T > 200\text{ МГц}$	SOT323.SC70	В·Е·С
1EP	2SC4084P	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_{CE} = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 82...180; f_T > 200\text{ МГц}$	SOT323.SC70	В·Е·С
1EP	BC847A	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1EQ	2SC4084Q	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_{CE} = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 120...270; f_T > 200\text{ МГц}$	SOT323.SC70	В·Е·С
1ER	BC847AR	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 310\text{ мВт}; h_{21} = 220; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	Е·В·С
1Es	BC847A	INF	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T = 250\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1Es	BC847A	INF	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T = 250\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1Es	BC847AT	INF	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T = 250\text{ МГц}$	SOT416.SC75A	В·Е·С
1Es	BC847AW	INF	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT323.SC70	В·Е·С
1Et	BC847A	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1Et	BC847AW	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT323.SC70	В·Е·С
1F	BC847B	CDIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1F	BC847B	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1F	BC847B	TOSH	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1F	BC847B	VISH	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 310\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1F	BC847B	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1F	BC847BF	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT490.SC89	В·Е·С
1F	BC847BLT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1F	BC847BT	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT416.SC75A	В·Е·С
1F	BC847BT	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT523	В·Е·С
1F	BC847BWT1	LRC	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT323.SC70	В·Е·С
1F	BC847BWT1	ON	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT323.SC70	В·Е·С
1F	BC847CT	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 420...800; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT523	В·Е·С
1F	IRLML6401	IR	pMOS	HEXFET; $V_{GS} = 12\text{ В}; I_D = 3.4\text{ А}; P_D = 1.3\text{ Вт}; R_{DS(on)} < 0.125\text{ Ом}$	SOT23.SOD23	Г·С·D
1F	KST5550	SAMS	npn	$V_{CE0} = 160\text{ В}; I_{CE} = 600\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} = 60...250; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1F	MMBT5550	MOT	npn	$V_{CE0} = 160\text{ В}; I_{CE} = 600\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} = 60...250$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1F-	BC847BW	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT323.SC70	В·Е·С
1FF	CMPT5551	CSI	npn	$V_{CE0} = 180\text{ В}; I_{CE} = 600\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} = 80...250; f_T = 100...300\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1FP	2SK321P	PAN	nFET	$V_{GS} = 15\text{ В}; I_D = 5\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_F > 15\text{ мСм}; I_{DSS} = 5...16\text{ мА}$	SOT23.SOD23	С·D·G
1FP	BC847B	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1FQ	2SK321Q	PAN	nFET	$V_{GS} = 15\text{ В}; I_D = 5\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_F > 15\text{ мСм}; I_{DSS} = 14...24\text{ мА}$	SOT23.SOD23	С·D·G
1FR	2SK321R	PAN	nFET	$V_{GS} = 15\text{ В}; I_D = 5\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_F > 15\text{ мСм}; I_{DSS} = 20...32\text{ мА}$	SOT23.SOD23	С·D·G
1FR	BC847BR	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 310\text{ мВт}; h_{21} = 330; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	Е·В·С
1FS	2SK321S	PAN	nFET	$V_{GS} = 15\text{ В}; I_D = 5\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_F > 15\text{ мСм}; I_{DSS} = 28...42\text{ мА}$	SOT23.SOD23	С·D·G
1Fs	BC847B	INF	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T = 250\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1Fs	BC847BT	INF	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T = 250\text{ МГц}$	SOT416.SC75A	В·Е·С
1Fs	BC847BW	INF	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T = 250\text{ МГц}$	SOT323.SC70	В·Е·С
1Ft	BC847B	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1Ft	BC847BW	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT323.SC70	В·Е·С
1FZ	FMBT5550	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 140\text{ В}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1G	BC847C	CDIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 310\text{ мВт}; h_{21} = 420...800; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1G	BC847C	VISH	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 310\text{ мВт}; h_{21} = 420...800; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1G	BC847C	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 420...800; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1G	BC847C	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} = 420...800; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1G	BC847CF	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 420...800; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT490.SC89	В·Е·С
1G	BC847CLT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} = 420...800; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23.SOD23	В·Е·С
1G	BC847CT	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 420...800; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT416.SC75A	В·Е·С
1G	BC847CWT1	LRC	npn	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{CE} = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 420...800; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT323.SC70	В·Е·С

**SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3**

**VMT3
VMD3**



**SOT416
SOT523**

**SOT323
SOT346**

**SOT23-3
SOD23-3**



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
1G	BC847CWT1	ON	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 420...800; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
1G	FMMTA06	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} > 50; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1G	JRLML2502	JR	nMOS	HEXFET; $V_{GS} = 30 В; I_D = 3.4 А; P_D = 1.25 Вт; R_{\theta(SJ)} < 0.08 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
1G	KST06	SAMS	npn	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} > 50; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1G	MMBTA06	VISH	npn	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 300 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} > 50; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1G	MMBTA06	MOT	npn	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 300 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} > 50; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1G	TMPTA06	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 80 В; I_{C(sat)} < 100 мА; h_{21} > 50; V_{CE(sat)} < 0.25 В; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1G-	BC847CW	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 420...800; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
1G-	BC847CW	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 420...800; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
1Gr	BC847C	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 420...800; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1GR	BC847CR	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45 В; I_C = 100 мА; P_D = 310 мВт; h_{21} = 600; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1Gs	BC847C	INF	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 420...800; f_T = 250 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1Gs	BC847CT	INF	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 420...800; f_T = 250 МГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
1Gsb	BC847CW	INF	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 420...800; f_T = 250 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
1Gt	BC847C	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 420...800; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1Gt	BC847CW	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 420...800; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
1GT	SOA06	STM	npn	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} > 50; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1GZ	BC847C	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 420...800; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1H	2SK123	PAN	nFET	$V_{DS} > 20 В; I_D = 2 мА; P_D = 200 мВт; g_m > 0.7 мСм$	SOT23, SOD23	D-S-G
1H	BC847	CDIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110...800; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1H	FMMTA05	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} > 50; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1H	JRLML5203	JR	pMOS	HEXFET; $V_{GS} = 30 В; I_D = 2.4 А; P_D = 1.25 Вт; R_{\theta(SJ)} < 0.165 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
1H	KST05	SAMS	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} > 50; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1H	MMBTA05	VISH	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 30 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} > 50; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1H	MMBTA05	MOT	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 30 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} > 50; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1H	TMPTA05	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_{C(sat)} < 100 мА; h_{21} > 50; V_{CE(sat)} < 0.25 В; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1H-	BC847W	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 110...800; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
1Hb	BC847	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110...800; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1Ht	BC847	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110...800; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1Ht	BC847W	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 110...800; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
1HT	SOA05	SGS	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 625 мВт; h_{21} > 100; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1J	BC848A	CDIL	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1J	BC848A	TOSH	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1J	BC848A	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1J	BC848A	VISH	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 310 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1J	BC848AF	PHIL	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 100 МГц$	SOT490, SC88	B-E-C
1J	BC848ALT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1J	BC848AW	PHIL	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
1J	BC848AWT1	ON	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
1J	FMMT2369	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 200 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 40...120$	SOT23, SOD23	B-E-C
1J	PMST2369	PHIL	npn	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 40...120$	SOT323, SC70	B-E-C
1JA	MMBT2369ALT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 200 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 40$	SOT23, SOD23	B-E-C
1Jp	BC848A	PHIL	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1JR	BC848AR	PHIL	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	C-B-E
1Js	BC848A	INF	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 110...220; f_T = 250 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1Js	BC848AT	INF	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110...220; f_T = 250 МГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
1Js	BC848AW	INF	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110...220; f_T = 250 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
1Jt	BC848A	PHIL	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1JZ	BC848A	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 110...220; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1K	BC848B	CDIL	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 310 мВт; h_{21} = 200...450; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
1K	BC848B	TOSH	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 200...450; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3
1K	BC848B	DIODS	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 300$ мВт; $h_{21} \sim 200...450$; $f_T \sim 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1K	BC848B	VISH	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 310$ мВт; $h_{21} \sim 200...450$; $f_T \sim 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1K	BC848B	ZETEX	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 330$ мВт; $h_{21} \sim 200...450$; $f_T \sim 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1K	BC848B	ITT	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 330$ мВт; $h_{21} \sim 200...450$; $f_T \sim 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1K	BC848BF	PHIL	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 250$ мВт; $h_{21} \sim 200...450$; $f_T \sim 100$ МГц	SOT490, SC89	В•Е•С
1K	BC848BLT1	MOT	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 300$ мВт; $h_{21} \sim 200...450$; $f_T \sim 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1K	BC848BW	PHIL	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 200$ мВт; $h_{21} \sim 200...450$; $f_T \sim 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1K	BC848BWT1	LRC	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 250$ мВт; $h_{21} \sim 200...450$; $f_T \sim 250$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1K	BC848BWT1	ON	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 250$ мВт; $h_{21} \sim 200...450$; $f_T \sim 250$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1K	FMMT4400	ZETEX	npn	$V_{CE0} \sim 60$ В; $I_C \sim 600$ мА; $P_D \sim 330$ мВт; $h_{21} \sim 50...150$; $f_T \sim 200$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1K	KST6428	SAMS	npn	$V_{CE0} \sim 60$ В; $I_C \sim 200$ мА; $P_D \sim 350$ мВт; $h_{21} \sim 250...650$; $f_T \sim 100...700$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1K	MMBT6428	MOT	npn	$V_{CE0} \sim 60$ В; $I_C \sim 200$ мА; $P_D \sim 300$ мВт; $h_{21} \sim 250...650$; $f_T \sim 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1K	PMST6428	PHIL	npn	$V_{CE0} \sim 60$ В; $I_C \sim 200$ мА; $P_D \sim 200$ мВт; $h_{21} \sim 250...650$; $f_T \sim 100...700$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1KP	2SK16P	PAN	nFET	$V_{GS} \sim 10$ В; $I_D \sim 5$ мА; $P_D \sim 200$ мВт; $g_m > 15$ мСм; $I_{DSS} \sim 5...16$ мА	SOT23, SOD23	С•D•G
1KP	BC848B	PHIL	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 250$ мВт; $h_{21} \sim 200...450$; $f_T \sim 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1KQ	2SK16Q	PAN	nFET	$V_{GS} \sim 10$ В; $I_D \sim 5$ мА; $P_D \sim 200$ мВт; $g_m > 15$ мСм; $I_{DSS} \sim 14...24$ мА	SOT23, SOD23	С•D•G
1KR	BC848BF	PHIL	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 310$ мВт; $h_{21} \sim 330$; $f_T \sim 300$ МГц	SOT23, SOD23	Е•В•С
1Ks	BC848B	INF	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 330$ мВт; $h_{21} \sim 200...450$; $f_T \sim 250$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Ks	BC848BT	INF	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 250$ мВт; $h_{21} \sim 200...450$; $f_T \sim 250$ МГц	SOT416, SC75A	В•Е•С
1Ks	BC848BW	INF	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 250$ мВт; $h_{21} \sim 200...450$; $f_T \sim 250$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1Kt	BC848B	PHIL	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 250$ мВт; $h_{21} \sim 200...450$; $f_T \sim 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1KZ	FMMT4400	ZETEX	npn	$V_{CE0} \sim 60$ В; $I_C \sim 600$ мА; $P_D \sim 330$ мВт; $h_{21} \sim 50...150$; $f_T \sim 200$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1L	BC848C	ITT	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 310$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1L	BC848C	CDIL	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 310$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1L	BC848C	DIODS	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 300$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1L	BC848C	TOSH	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 150$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1L	BC848C	VISH	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 310$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1L	BC848CF	PHIL	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 250$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 100$ МГц	SOT490, SC89	В•Е•С
1L	BC848CLT1	MOT	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 300$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1L	BC848CW	PHIL	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 200$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1L	BC848CWT1	LRC	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 250$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 250$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1L	BC848CWT1	ON	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 250$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 250$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1L	FMMT4401	ZETEX	npn	$V_{CE0} \sim 60$ В; $I_C \sim 600$ мА; $P_D \sim 330$ мВт; $h_{21} \sim 100...300$; $f_T \sim 250$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1L	MMBT6429	MOT	npn	$V_{CE0} \sim 55$ В; $I_C \sim 200$ мА; $P_D \sim 300$ мВт; $h_{21} \sim 500...1250$; $f_T \sim 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1L	PMST6429	PHIL	npn	$V_{CE0} \sim 55$ В; $I_C \sim 200$ мА; $P_D \sim 200$ мВт; $h_{21} \sim 500...1250$; $f_T \sim 100...700$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1LM	2SC4103M	ROHM	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 30$ мА; $P_D \sim 200$ мВт; $h_{21} \sim 39...82$; $f_T \sim 110$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1LN	2SC4103N	ROHM	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 30$ мА; $P_D \sim 200$ мВт; $h_{21} \sim 56...120$; $f_T \sim 110$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1LP	2SC4103P	ROHM	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 30$ мА; $P_D \sim 200$ мВт; $h_{21} \sim 82...180$; $f_T \sim 110$ МГц	SOT23, SC70	В•Е•С
1LP	2SK247P	PAN	nFET	$V_{GS} \sim 15$ В; $I_D \sim 20$ мА; $P_D \sim 150$ мВт; $g_m > 3$ мСм; $I_{DSS} \sim 0.5...1.5$ мА	SOT23, SOD23	С•D•G
1Lp	BC848C	PHIL	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 250$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1LQ	2SC4103Q	ROHM	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 30$ мА; $P_D \sim 200$ мВт; $h_{21} \sim 120...270$; $f_T \sim 110$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1LQ	2SK247Q	PAN	nFET	$V_{GS} \sim 15$ В; $I_D \sim 20$ мА; $P_D \sim 150$ мВт; $g_m > 3$ мСм; $I_{DSS} \sim 1...3$ мА	SOT23, SOD23	С•D•G
1LR	2SK247R	PAN	nFET	$V_{GS} \sim 15$ В; $I_D \sim 20$ мА; $P_D \sim 150$ мВт; $g_m > 3$ мСм; $I_{DSS} \sim 2...6$ мА	SOT23, SOD23	С•D•G
1LR	BC848CR	PHIL	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 310$ мВт; $h_{21} \sim 600$; $f_T \sim 300$ МГц	SOT23, SOD23	Е•В•С
1LS	2SK247S	PAN	nFET	$V_{GS} \sim 15$ В; $I_D \sim 20$ мА; $P_D \sim 150$ мВт; $g_m > 3$ мСм; $I_{DSS} \sim 4...12$ мА	SOT23, SOD23	С•D•G
1Ls	BC848C	INF	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 330$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 250$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Ls	BC848CT	INF	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 330$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 250$ МГц	SOT416, SC75A	В•Е•С
1Ls	BC848CW	INF	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 250$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 250$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
1Lt	BC848C	PHIL	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 250$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1M	BC848	DIODS	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 250$ мВт; $h_{21} \sim 110...800$; $f_T \sim 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
1M	BC848C	CDIL	npn	$V_{CE0} \sim 30$ В; $I_C \sim 100$ мА; $P_D \sim 300$ мВт; $h_{21} \sim 420...800$; $f_T \sim 300$ МГц	SOT523	В•Е•С
1M	FMMTA13	ZETEX	npn	$V_{CE0} \sim 40$ В; $I_C \sim 300$ мА; $P_D \sim 330$ мВт; $h_{21} > 10000$	SOT23, SOD23	В•Е•С

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	С	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
1M	KST13	SAMS	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 300\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} > 5000; f_T > 125\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1M	MMBT413	VISH	dnprn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 300\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} < 10000; f_T < 125\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1M	MMBT413LT1	MOT	dnprn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 300\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 5000; f_T > 125\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1M-	BC848W	PHIL	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 110...800; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
1MN	2SC4128N	ROHM	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 56...120; f_T > 230\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
1MP	2SC4128P	ROHM	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 82...180; f_T > 230\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
1MP	2SJ84P	PAN	pFET	$V_{DS} = 15\text{ В}; I_D = 10\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_F = 9\text{ мСм}$	SOT23,SOD23	D•S•G
1Mp	BC848	PHIL	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 110...800; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1MQ	2SJ84Q	PAN	pFET	$V_{DS} = 15\text{ В}; I_D = 10\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_F = 9\text{ мСм}$	SOT23,SOD23	D•S•G
1MR	2SJ84R	PAN	pFET	$V_{DS} = 15\text{ В}; I_D = 10\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_F = 9\text{ мСм}$	SOT23,SOD23	D•S•G
1Mt	BC848W	PHIL	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 110...800; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SC70	B•E•C
1N	FMMTA14	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 300\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} > 20000$	SOT23,SOD23	B•E•C
1N	KST14	SAMS	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 300\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} > 10000; f_T > 125\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1N	MMBT3904	VISH	npn	$V_{CEB} = 60\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1N	MMBT414	VISH	dnprn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 300\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} < 20000; f_T < 125\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1N	MMBT414LT1	MOT	dnprn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 300\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 10000; f_T > 125\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1N	TMPA14	ALLEG	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_{CBQ} < 100\text{ нА}; h_{21} > 20 \times; V_{CE(sat)} < 1.5\text{ В}; f_T > 125\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1N5	ZTX11N15DF	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 15\text{ В}; I_C = 3\text{ А}$	SOT23,SOD23	B•E•C
10P	2SK662P	PAN	nFET	$V_{DS} = 30\text{ В}; I_D = 20\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; g_F > 4\text{ мСм}; I_{SS} = 0.5...3\text{ мА}$	SOT323,SC70	S•D•G
10P	2SK662Q	PAN	nFET	$V_{DS} = 30\text{ В}; I_D = 20\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; g_F > 4\text{ мСм}; I_{SS} = 2...6\text{ мА}$	SOT323,SC70	S•D•G
10R	2SK662R	PAN	nFET	$V_{DS} = 30\text{ В}; I_D = 20\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; g_F > 4\text{ мСм}; I_{SS} = 4...12\text{ мА}$	SOT323,SC70	S•D•G
1P	FMMT2222A	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 75\text{ В}; I_C = 600\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} > 120...360; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1P	KST2222A	SAMS	npn	$V_{CEB} = 75\text{ В}; I_C = 600\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} > 75; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1P	MBT2222A	TOSH	npn	$V_{CEB} = 75\text{ В}; I_C = 600\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 40; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1P	MMBT2222A	VISH	npn	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 800\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 200\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1P	MMBT2222ALT1	MOT	npn	$V_{CEB} = 75\text{ В}; I_C = 600\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 35; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1P	MMBT2222LT1	ON	npn	$V_{CEB} = 60\text{ В}; I_C = 600\text{ мА}; P_D = 225\text{ мВт}; h_{21} > 30$	SOT23,SOD23	B•E•C
1P	TMP2222A	ALLEG	npn	$V_{CEB} = 75\text{ В}; I_{CBQ} < 10\text{ нА}; h_{21} > 100...300; V_{CE(sat)} < 0.3\text{ В}; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
-1P	PMST2222A	PHIL	npn	$V_{CEB} = 75\text{ В}; I_C = 600\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
1Q	FMMT5088	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 35\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} > 300...900; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1Q	KST5088	SAMS	npn	$V_{CEB} = 35\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} > 300...900; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1Q	MMBT5088	VISH	npn	$V_{CEB} = 35\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} > 300...900; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1Q	MMBT5088	MOT	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} > 350...1400; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1Q	TMP25088	ALLEG	npn	$V_{CEB} = 35\text{ В}; I_{CBQ} < 50\text{ нА}; h_{21} > 300...900; V_{CE(sat)} < 0.5\text{ В}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1R	FMMT5089	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} > 400...1200; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1R	KST5089	SAMS	npn	$V_{CEB} = 35\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} > 400...1200; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1R	MMBT5089	VISH	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} > 400...1200; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1R	MMBT5089	MOT	npn	$V_{CEB} = 25\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} > 450...1800; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1R	TMP5089	ALLEG	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_{CBQ} < 50\text{ нА}; h_{21} > 400...1200; V_{CE(sat)} < 0.5\text{ В}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1S	MMBT2369A	FAIR	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; P_D = 225\text{ мВт}; h_{21} > 40$	SOT23,SOD23	B•E•C
1S	MSC3130	MOT	npn	$V_{CEB} = 10\text{ В}; f_T = 1.4\text{ ГГц}$	SOT346,SC59	B•E•C
1SP	2SC3130P	PAN	npn	$V_{CEB} = 15\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 75...130; f_T = 1.9\text{ ГГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1SP	2SC3935P	PAN	npn	$V_{CEB} = 15\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 75...130; f_T = 1.9\text{ ГГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
1SP	2SC4809P	PAN	npn	$V_{CEB} = 15\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 125\text{ мВт}; h_{21} > 75...130; f_T = 1.4...2.7\text{ ГГц}$	SOT416,SC75A	B•E•C
1SQ	2SC3130Q	PAN	npn	$V_{CEB} = 15\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 110...220; f_T = 1.9\text{ ГГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1SQ	2SC3935Q	PAN	npn	$V_{CEB} = 15\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 110...220; f_T = 1.9\text{ ГГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
1SQ	2SC4809Q	PAN	npn	$V_{CEB} = 15\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 125\text{ мВт}; h_{21} > 110...220; f_T = 1.4...2.7\text{ ГГц}$	SOT416,SC75A	B•E•C
1SR	2SC4809R	PAN	npn	$V_{CEB} = 15\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 125\text{ мВт}; h_{21} > 200...400; f_T = 1.4...2.7\text{ ГГц}$	SOT416,SC75A	B•E•C
1T	2SC3933T	PAN	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 20\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 40...200; f_T > 750\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
1T1	MMST5101	ROHM	npn	$V_{CEB} = 60\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; h_{21} > 200...400; f_T > 125\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
1T1	SST5101	ROHM	npn	$V_{CEB} = 60\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; h_{21} > 200...400; f_T > 125\text{ МГц}$	SOT346,SC59	B•E•C
1U	2SC3110	PAN	npn	$V_{CEB} = 15\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 40; f_T = 4.5\text{ ГГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TSM VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
1U	2SC3934	PAN	npn	$V_{CE0} = 15 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 40; f_T > 4.5 \text{ ГГц}$	SOT323, SC70	В•Е•С
1U	KST2484	SAMS	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} > 250$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1U	MMBT2494LT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 225 \text{ мВт}; h_{21} > 250$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1V	BF820	CDIL	npn	$V_{CE0} = 300 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1V	MMBT6427	MOT	npn	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 225 \text{ мВт}; h_{21} > 10000$	SOT23, SOD23	Е•В•С
1V	TMP76427	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_{CB0} = 50 \text{ мА}; h_{21} = 10000...100000; V_{CE(sat)} < 1.2 \text{ В}; f_T > 130 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1V-	BF820W	PHIL	npn	$V_{CE0} = 300 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	В•Е•С
1Vp	BF820	PHIL	npn	$V_{CE0} = 300 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1VR	2SD1149R	PAN	npn	$V_{CE0} = 100 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 400...800$	SOT346, SC59	В•Е•С
1VR	2SD1824R	PAN	npn	$V_{CE0} = 100 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 400...800; f_T = 90 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	В•Е•С
1VS	2SD1149S	PAN	npn	$V_{CE0} = 100 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 600...1200$	SOT346, SC59	В•Е•С
1VS	2SD1824S	PAN	npn	$V_{CE0} = 100 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 600...1200; f_T = 90 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	В•Е•С
1VT	2SD1149T	PAN	npn	$V_{CE0} = 100 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 800...2000$	SOT346, SC59	В•Е•С
1VT	2SD1824T	PAN	npn	$V_{CE0} = 100 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 1000...2000; f_T = 90 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	В•Е•С
1Vt	BF820	PHIL	npn	$V_{CE0} = 300 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Vt	BF820W	PHIL	npn	$V_{CE0} = 300 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	В•Е•С
1W	BF821	CDIL	pnp	$V_{CE0} = 300 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1W	FMMT3903	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 50...150; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1W-	BF822W	PHIL	npn	$V_{CE0} = 250 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	В•Е•С
1Wp	BF821	PHIL	pnnp	$V_{CE0} = 300 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Wt	BF821	PHIL	pnnp	$V_{CE0} = 300 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Wt	BF822W	PHIL	npn	$V_{CE0} = 250 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	В•Е•С
1X	BF822	CDIL	npn	$V_{CE0} = 250 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1X	MMBT3903L	MOT	npn	$V_{CE0} = 45 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 225 \text{ мВт}; h_{21} = 100...300; f_T > 30 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Xp	BF822	PHIL	npn	$V_{CE0} = 250 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Xl	BF822	PHIL	npn	$V_{CE0} = 250 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Y	BF823	CDIL	pnnp	$V_{CE0} = 250 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Y	KST3903	SAMS	pnnp	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 50...150; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Y	MMBT3903	MOT	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} > 15$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Yp	BF823	PHIL	pnnp	$V_{CE0} = 250 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Yt	BF823	PHIL	pnnp	$V_{CE0} = 250 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1Z	BAS7006	ZETEX	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; V_F(I_F = 1 \text{ мА}) < 0.41 \text{ В}; I_S < 0.2 \text{ мкА}; C_0 < 2.0 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
1Z	BAS70-06	ZETEX	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_F < 70 \text{ мА}; V_F(I_F = 1 \text{ мА}) < 410 \text{ мВ}; C_0 < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
1Z	MMBT6517	MOT	npn	$V_{CE0} = 350 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 20...200; f_T > 40 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
1ZR	2SD1030R	PAN	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 400...800$	SOT346, SC59	В•Е•С
1ZR	2SD1823R	PAN	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 400...800; f_T = 120 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	В•Е•С
1ZR	2SD2345R	PAN	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 125 \text{ мВт}; h_{21} = 400...800; f_T = 120 \text{ МГц}$	SOT416, SC75A	В•Е•С
1ZS	2SD1030S	PAN	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 600...1200$	SOT346, SC59	В•Е•С
1ZS	2SD1823S	PAN	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 600...1200; f_T = 120 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	В•Е•С
1ZS	2SD2345S	PAN	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 125 \text{ мВт}; h_{21} = 600...1200; f_T = 120 \text{ МГц}$	SOT416, SC75A	В•Е•С
1ZT	2SD1030T	PAN	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 1000...2000$	SOT346, SC59	В•Е•С
1ZT	2SD1823T	PAN	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 1000...2000; f_T = 120 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	В•Е•С
1ZT	2SD2345T	PAN	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 125 \text{ мВт}; h_{21} = 1000...2000; f_T = 120 \text{ МГц}$	SOT416, SC75A	В•Е•С
2.0X	02C22.0	TOSH	dz	$V_F(I_F = 5 \text{ мА}) = 1.85...2.15 \text{ В}; I_C(V_F = 0.5 \text{ В}) < 120 \text{ мкА}; Z_T(f_T = 0.5 \text{ мА}) < 1000 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A•n.c.•K
2.2X	02C22.2	TOSH	dz	$V_F(I_F = 5 \text{ мА}) = 2.05...2.38 \text{ В}; I_C(V_F = 1.0 \text{ В}) < 120 \text{ мкА}; Z_T(f_T = 0.5 \text{ мА}) < 1000 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A•n.c.•K
2.4X	02C22.4	TOSH	dz	$V_F(I_F = 5 \text{ мА}) = 2.28...2.60 \text{ В}; I_C(V_F = 1.0 \text{ В}) < 120 \text{ мкА}; Z_T(f_T = 0.5 \text{ мА}) < 1000 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A•n.c.•K
2.7X	02C22.7	TOSH	dz	$V_F(I_F = 5 \text{ мА}) = 2.50...2.90 \text{ В}; I_C(V_F = 1.0 \text{ В}) < 120 \text{ мкА}; Z_T(f_T = 0.5 \text{ мА}) < 1000 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A•n.c.•K
200	SSTPAD200	SIL	dl	$V_B = 55 \text{ В}; I_C < 10 \text{ мА}; V_F(I_F = 1 \text{ мА}) < 1.5 \text{ В}; I_S < 200 \text{ нА}; C_0 < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K•K•A
20A	MMBZ20VAL	ON	dz-2	$V_F(I_F = 1 \text{ мА}) = 19...21 \text{ В}; V_F(I_F = 10 \text{ мА}) < 0.9 \text{ В}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
20p	BF545A	PHIL	nFET	$V_{DS}=30\text{ В}; I_{DSS}=6.5\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; g_{fs}=3\text{...}6.5\text{ мС}$	SOT23,SOD23	S-D-G
20t	BF545A	PHIL	nFET	$V_{DS}=30\text{ В}; I_{DSS}=6.5\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; g_{fs}=3\text{...}6.5\text{ мС}$	SOT23,SOD23	S-D-G
20V	PZM20NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ мА})=18.86\text{...}21.08\text{ В}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ мА}) < 20\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
20W	BF545A	PHIL	nFET	$V_{DS}=30\text{ В}; I_{DSS}=6.5\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; g_{fs}=3\text{...}6.5\text{ мС}$	SOT23,SOD23	S-D-G
20W	SO2222AW	SGS	npn	$V_{CEB}=75\text{ В}; I_C=800\text{ мА}; P_D=310\text{ мВт}; h_{21}=100\text{...}300; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT323,SC70	S-D-G
20X	O2C220	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ мА})=18.80\text{...}21.20\text{ В}; I_C(V_{CE}=15\text{ В}) < 0.5\text{ мА}; Z_{T1}(I_{ZT}=0.5\text{ мА}) < 200\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
210	KTY82-210	PHIL	rts	$T_{AMB}=-55\text{...}150\text{ }^\circ\text{C}; R_{25}=1980\text{...}2020\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	CONT1-CONT2-SUB
21p	BF545B	PHIL	nFET	$V_{DS}=30\text{ В}; I_{DSS}=15\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; g_{fs}=3\text{...}6.5\text{ мС}$	SOT23,SOD23	S-D-G
21t	BF545B	PHIL	nFET	$V_{DS}=30\text{ В}; I_{DSS}=15\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; g_{fs}=3\text{...}6.5\text{ мС}$	SOT23,SOD23	S-D-G
21W	BF545B	PHIL	nFET	$V_{DS}=30\text{ В}; I_{DSS}=15\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; g_{fs}=3\text{...}6.5\text{ мС}$	SOT23,SOD23	S-D-G
22	DTC123EE	ROHM	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>20; f_T > 250\text{ МГц}; R_{11}/R_{22}=2.2/2.2\text{ кОм}$	SOT416,SC75A	B-E-C
22	DTC123EKA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>20; f_T > 250\text{ МГц}; R_{11}/R_{22}=2.2/2.2\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
22	DTC123EUA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>20; f_T > 250\text{ МГц}; R_{11}/R_{22}=2.2/2.2\text{ кОм}$	SOT323,SC70	B-E-C
22	MMBT4209	MOT	npn	$V_{CEB}=15\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>35; f_T=850\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
220	KTY82-220	PHIL	rts	$T_{AMB}=-55\text{...}150\text{ }^\circ\text{C}; R_{25}=1960\text{...}2040\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	CONT1-CONT2-SUB
221	KTY82-221	PHIL	rts	$T_{AMB}=-55\text{...}150\text{ }^\circ\text{C}; R_{25}=1960\text{...}2000\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	CONT1-CONT2-SUB
222	KTY82-222	PHIL	rts	$T_{AMB}=-55\text{...}150\text{ }^\circ\text{C}; R_{25}=2000\text{...}2040\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	CONT1-CONT2-SUB
22p	BF545C	PHIL	nFET	$V_{DS}=30\text{ В}; I_{DSS}=25\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; g_{fs}=3\text{...}6.5\text{ мС}$	SOT23,SOD23	S-D-G
22t	BF545C	PHIL	nFET	$V_{DS}=30\text{ В}; I_{DSS}=25\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; g_{fs}=3\text{...}6.5\text{ мС}$	SOT23,SOD23	S-D-G
22V	PZM22NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ мА})=20.88\text{...}23.17\text{ В}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ мА}) < 25\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
22W	BF545C	PHIL	nFET	$V_{DS}=30\text{ В}; I_{DSS}=25\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; g_{fs}=3\text{...}6.5\text{ мС}$	SOT23,SOD23	S-D-G
22X	O2C222	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ мА})=20.80\text{...}23.30\text{ В}; I_C(V_{CE}=17\text{ В}) < 0.5\text{ мА}; Z_{T1}(I_{ZT}=0.5\text{ мА}) < 200\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
23	DTC143EE	ROHM	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>20; f_T > 250\text{ МГц}; R_{11}/R_{22}=4.7/4.7\text{ кОм}$	SOT416,SC75A	B-E-C
23	DTC143EKA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>20; f_T > 250\text{ МГц}; R_{11}/R_{22}=4.7/4.7\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
23	DTC143EUA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>20; f_T > 250\text{ МГц}; R_{11}/R_{22}=4.7/4.7\text{ кОм}$	SOT323,SC70	B-E-C
23	PDTA114TK	PHIL	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>200; R_1=10\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
24	DTC114EE	ROHM	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>30; f_T > 250\text{ МГц}; R_{11}/R_{22}=10/10\text{ кОм}$	SOT416,SC75A	B-E-C
24	DTC114EKA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>30; f_T > 250\text{ МГц}; R_{11}/R_{22}=10/10\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
24	DTC114EUA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>30; f_T > 250\text{ МГц}; R_{11}/R_{22}=47/47\text{ кОм}$	SOT323,SC70	B-E-C
24	MMBT3646	ON	npn	$V_{CEB}=40\text{ В}; I_C=300\text{ мА}; P_D=625\text{ мВт}; h_{21}>15$	SOT23,SOD23	B-E-C
24	PDTC114TE	PHIL	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>200; R_1=10\text{ кОм}$	SOT416,SC75A	B-E-C
24	PDTC114TK	PHIL	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>200; R_1=10\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
24p	BF556A	PHIL	nFET	$V_{DS}=30\text{ В}; I_{DSS}=7\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; g_{fs}>4.5\text{ мС}$	SOT23,SOD23	S-D-G
24t	BF556A	PHIL	nFET	$V_{DS}=30\text{ В}; I_{DSS}=7\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; g_{fs}>4.5\text{ мС}$	SOT23,SOD23	S-D-G
24V	PZM24NB	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ мА})=22.93\text{...}25.57\text{ В}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ мА}) < 30\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
24W	BF556A	PHIL	nFET	$V_{DS}=30\text{ В}; I_{DSS}=7\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; g_{fs}>4.5\text{ мС}$	SOT23,SOD23	S-D-G
24X	O2C224	TOSH	dz	$V_Z(I_{ZT}=5\text{ мА})=22.80\text{...}25.60\text{ В}; I_C(V_{CE}=19\text{ В}) < 0.5\text{ мА}; Z_{T1}(I_{ZT}=0.5\text{ мА}) < 200\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
25	DTC124EE	ROHM	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_{C(MIN)}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>56; f_T > 250\text{ МГц}; R_{11}/R_{22}=22/22\text{ кОм}$	SOT416,SC75A	B-E-C
25	DTC124EKA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=30\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>56; f_T > 250\text{ МГц}; R_{11}/R_{22}=22/22\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
25	DTC124EUA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=30\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>56; f_T > 250\text{ МГц}; R_{11}/R_{22}=22/22\text{ кОм}$	SOT323,SC70	B-E-C
25	MMBD1202	ON	di	$V_R < 100\text{ В}; I_C < 200\text{ мА}; V_{F(I_F=200\text{ мА})} < 1\text{ В}; C_0 < 2\text{ пФ}; I_{RR} < 3\text{ мС}$	SOT23,SOD23	n.c.-A-K



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
25	РДА143ХК	PHIL	Dnpn	$V_{CBO} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} > 50$; $4,7$ кОм/10 кОм	SOT346,SC59	В•Е•С
250	КТY82-250	PHIL	rts	$T_{AMB} = -55...150$ °C; $R_{25} = 1900...2100$ Ом	SOT23,SOD23	CONT1- CONT2-SUB
251	КТY82-251	PHIL	rts	$T_{AMB} = -55...150$ °C; $R_{25} = 1900...2000$ Ом	SOT23,SOD23	CONT1- CONT2-SUB
252	КТY82-252	PHIL	rts	$T_{AMB} = -55...150$ °C; $R_{25} = 2000...2100$ Ом	SOT23,SOD23	CONT1- CONT2-SUB
25p	BF556B	PHIL	nFET	$V_{DS} = 30$ В; $I_{DSS} = 13$ мА; $P_D = 250$ мВт; $g_m > 4,5$ мС	SOT23,SOD23	S•D•G
25t	BF556B	PHIL	nFET	$V_{DS} = 30$ В; $I_{DSS} = 13$ мА; $P_D = 250$ мВт; $g_m > 4,5$ мС	SOT23,SOD23	S•D•G
25W	BF556B	PHIL	nFET	$V_{DS} = 30$ В; $I_{DSS} = 13$ мА; $P_D = 250$ мВт; $g_m > 4,5$ мС	SOT23,SOD23	S•D•G
26	DTC144EE	ROHM	Dnpn	$V_{CBO} = 50$ В; $I_{C(max)} = 100$; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} > 68$; $f_T > 250$ МГц; $R_1/R_2 = 47/47$ кОм	SOT416,SC75A	В•Е•С
26	DTC144EK	ROHM	Dnpn	$V_{CBO} = 50$ В; $I_C = 30$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 68$; $f_T > 250$ МГц; $R_1/R_2 = 47/47$ кОм	SOT346,SC59	В•Е•С
26	DTC144EUA	ROHM	Dnpn	$V_{CBO} = 50$ В; $I_C = 30$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 68$; $f_T > 250$ МГц; $R_1/R_2 = 47/47$ кОм	SOT323,SC70	В•Е•С
26	MMBD1203	FAIR	di-2	$V_A = 100$ В; $I_F < 200$ мА; $V_{FI(F)} = 200$ мА < 1 В; $C_0 < 2$ нФ; $I_{DSS} < 3$ нС	SOT23,SOD23	A1•K2-K1,A2
26	PDTС143ХК	PHIL	Dnpn	$V_{CBO} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} > 50$; $4,7$ кОм/10 кОм	SOT346,SC59	В•Е•С
26p	BF556C	PHIL	nFET	$V_{DS} = 30$ В; $I_{DSS} = 18$ мА; $P_D = 250$ мВт; $g_m > 4,5$ мС	SOT23,SOD23	S•D•G
26t	BF556C	PHIL	nFET	$V_{DS} = 30$ В; $I_{DSS} = 18$ мА; $P_D = 250$ мВт; $g_m > 4,5$ мС	SOT23,SOD23	S•D•G
26W	BF556C	PHIL	nFET	$V_{DS} = 30$ В; $I_{DSS} = 18$ мА; $P_D = 250$ мВт; $g_m > 4,5$ мС	SOT23,SOD23	S•D•G
27	MMBD1204	FAIR	di-2	$V_A = 100$ В; $I_F < 200$ мА; $V_{FI(F)} = 200$ мА < 1 В; $C_0 < 2$ нФ; $I_{DSS} < 3$ нС	SOT23,SOD23	A1•A2-K1,K2
27A	MMB220VAL	ON	dz-2	$V_{Z1(Z2)} = 1$ МА; $25.65...28.35$ В; $V_{Z1(F)} = 10$ МА < 0.9 В	SOT23,SOD23	K1•K2-A1,A2
27V	PZM27NB	PHIL	dz	$V_{Z1(Z2)} = 2$ МА; $25.1...28.9$ В; $Z_{T1(Z2)} = 2$ МА < 40 Ом	SOT346,SC59	A•n.c•K
27X	02C227	TOSH	dz	$V_{Z1(Z2)} = 2$ МА; $25.10...28.90$ В; $I_T(V_{Z1}) = 21$ В < 0.5 мкА; $Z_{T1(Z2)} = 0.5$ МА < 250 Ом	SOT346,SC59	A•n.c•K
28	MMBD1205	FAIR	di-2	$V_A < 100$ В; $I_F < 200$ мА; $V_{FI(F)} = 200$ мА < 1 В; $C_0 < 2$ нФ; $I_{DSS} < 3$ нС	SOT23,SOD23	K1•K2-A1,A2
28p	BF861A	PHIL	nFET	$V_{DS} = 25$ В; $I_{DSS} = 6.5$ мА; $P_D = 250$ мВт; $g_m > 12$ мС	SOT23,SOD23	S•D•G
28t	BF861A	PHIL	nFET	$V_{DS} = 25$ В; $I_{DSS} = 6.5$ мА; $P_D = 250$ мВт; $g_m > 12$ мС	SOT23,SOD23	S•D•G
28W	BF861A	PHIL	nFET	$V_{DS} = 25$ В; $I_{DSS} = 6.5$ мА; $P_D = 250$ мВт; $g_m > 12$ мС	SOT23,SOD23	S•D•G
29	DTC115EE	ROHM	Dnpn	$V_{CBO} = 50$ В; $I_{C(max)} = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} > 82$; $f_T > 250$ МГц; $R_1/R_2 = 100/100$ кОм	SOT416,SC75A	В•Е•С
29	DTC115EKA	ROHM	Dnpn	$V_{CBO} = 50$ В; $I_C = 20$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 82$; $f_T > 250$ МГц; $R_1/R_2 = 100/100$ кОм	SOT346,SC59	В•Е•С
29	DTC115EUA	ROHM	Dnpn	$V_{CBO} = 50$ В; $I_C = 30$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 82$; $f_T > 250$ МГц; $R_1/R_2 = 100/100$ кОм	SOT323,SC70	В•Е•С
29	MMBD1401	FAIR	d	$V_A < 175$ В; $I_F < 600$ мА; $V_{FI(F)} = 200$ мА < 1 В; $I_S < 0.1$ мкА; $C_0 < 2$ нФ	SOT23,SOD23	A•n.c•K
29p	BF861B	PHIL	nFET	$V_{DS} = 25$ В; $I_{DSS} = 15$ мА; $P_D = 250$ мВт; $g_m > 16$ мС	SOT23,SOD23	S•D•G
29t	BF861B	PHIL	nFET	$V_{DS} = 25$ В; $I_{DSS} = 15$ мА; $P_D = 250$ мВт; $g_m > 16$ мС	SOT23,SOD23	S•D•G
29W	BF861B	PHIL	nFET	$V_{DS} = 25$ В; $I_{DSS} = 15$ мА; $P_D = 250$ мВт; $g_m > 16$ мС	SOT23,SOD23	S•D•G
2A	FMMT3906	ZETEX	npn	$V_{CBO} = 40$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 100...300$; $f_T > 250$ МГц	SOT23,SOD23	В•Е•С
2A	KST3906	SAMS	npn	$V_{CBO} = 40$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 350$ мВт; $h_{21} = 100...300$; $f_T > 250$ МГц	SOT23,SOD23	В•Е•С
2A	MMBT3906	VISH	npn	$V_{CBO} = 40$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 100...300$; $f_T > 250$ МГц	SOT23,SOD23	В•Е•С
2A	MMBT3906LT1	MOT	npn	$V_{CBO} = 40$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} = 100...300$; $f_T > 250$ МГц	SOT23,SOD23	В•Е•С
2A	MMBT3906WT1	MOT	npn	$V_{CBO} = 40$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 300$ мВт; $h_{21} = 100...300$; $f_T > 250$ МГц	SOT323,SC70	В•Е•С
2A	TMPT3906	ALLEG	npn	$V_{CBO} = 40$ В; $h_{21} = 100...300$; $V_{CE(sat)} < 0.25$ В; $f_T > 250$ МГц	SOT23,SOD23	В•Е•С
2A4	PZM2.4NB2A	PHIL	dz-2	$V_{Z1(Z2)} = 5$ МА; $2.3...2.6$ В; $Z_{T1(Z2)} = 5$ МА < 100 Ом	SOT346,SC59	K1•K2-A1,A2
2A7	PZM2.7NB2A	PHIL	dz-2	$V_{Z1(Z2)} = 5$ МА; $2.65...2.9$ В; $Z_{T1(Z2)} = 5$ МА < 100 Ом	SOT346,SC59	K1•K2-A1,A2
2AQ	2SD1304Q	PAN	npn	$V_{CBO} = 20$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 160...260$	SOT23,SOD23	В•Е•С
2AR	2SD1304R	PAN	npn	$V_{CBO} = 20$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 210...340$	SOT23,SOD23	В•Е•С
2AS	2SD1304S	PAN	npn	$V_{CBO} = 20$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 290...460$	SOT23,SOD23	В•Е•С
2B	BC849B	ITT	npn	$V_{CBO} = 30$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 300$ МГц	SOT23,SOD23	В•Е•С
2B	BC849B	CDIL	npn	$V_{CBO} = 30$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 300$ МГц	SOT23,SOD23	В•Е•С
2B	BC849B	TOSH	npn	$V_{CBO} = 30$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 300$ МГц	SOT23,SOD23	В•Е•С
2B	BC849B	ZETEX	npn	$V_{CBO} = 30$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 300$ МГц	SOT23,SOD23	В•Е•С
2B	FMMT2907	ZETEX	npn	$V_{CBO} = 60$ В; $I_C = 600$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 100...300$; $f_T > 200$ МГц	SOT23,SOD23	В•Е•С

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
2B	KST2907	SAMS	npn	$V_{CE0} < 60 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 75; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2B	MMBT2907	VISH	npn	$V_{CE0} < 40 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 310 \text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2B	MMBT2907	MOT	npn	$V_{CE0} < 40 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 310 \text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2B	TMPT2907	ALLEG	npn	$V_{CE0} < 60 \text{ В}; I_{CE0} < 20 \text{ мА}; h_{21} > 100...300; V_{CE(sat)} < 0.4 \text{ В}; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2B-	BC849BW	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 200...450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
2BP	2SK374P	PAN	nFET	$V_{DS} < 55 \text{ В}; I_D < 10 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; g_{fs} > 2.5 \text{ мСм}; I_{DSS} < 1...3 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	S•D•G
2BP	2SK663P	PAN	nFET	$V_{DS} < 55 \text{ В}; I_D < 30 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; g_{fs} > 2.5 \text{ мСм}; I_{DSS} < 1...3 \text{ мА}$	SOT323,SC70	S•D•G
2BP	BC849B	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 200...450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2BQ	2SK374Q	PAN	nFET	$V_{DS} < 55 \text{ В}; I_D < 10 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; g_{fs} > 2.5 \text{ мСм}; I_{DSS} < 2...6.5 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	S•D•G
2BQ	2SK663Q	PAN	nFET	$V_{DS} < 55 \text{ В}; I_D < 30 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; g_{fs} > 2.5 \text{ мСм}; I_{DSS} < 2...6.5 \text{ мА}$	SOT23,SC70	S•D•G
2BQ	2SK374R	PAN	nFET	$V_{DS} < 55 \text{ В}; I_D < 10 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; g_{fs} > 2.5 \text{ мСм}; I_{DSS} < 5...12 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	S•D•G
2BR	2SK663R	PAN	nFET	$V_{DS} < 55 \text{ В}; I_D < 30 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; g_{fs} > 2.5 \text{ мСм}; I_{DSS} < 5...12 \text{ мА}$	SOT323,SC70	S•D•G
2BR	BC849BR	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 310 \text{ мВт}; h_{21} > 330; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	E•B•C
2BS	2SK374S	PAN	nFET	$V_{DS} < 55 \text{ В}; I_D < 10 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; g_{fs} > 2.5 \text{ мСм}; I_{DSS} < 10...20 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	S•D•G
2Bs	BC849B	INF	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 200...450; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2Bs	BC849BT	INF	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 200...450; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT416,SC75A	B•E•C
2Bs	BC849BW	INF	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 200...450; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
2Bt	BC849B	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 200...450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2Bt	BC849BW	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 200...450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
2BZ	FMMT2907	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 60 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2C	BC849C	ITT	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2C	BC849C	CDIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2C	BC849C	TOSH	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2C	BC849C	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2C	BC849C	ITT	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2C	TMPTA70	ALLEG	npn	$I_{CE0} < 100 \text{ мА}; h_{21} > 40...100; V_{CE(sat)} < 0.25 \text{ В}; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2C-	BC849CW	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
2Cp	BC849C	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2Cr	BC849CR	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 310 \text{ мВт}; h_{21} > 600; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	E•B•C
2CS	BC849C	INF	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2Cs	BC849CT	INF	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT416,SC75A	B•E•C
2Cs	BC849CW	INF	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
2Cl	BC849C	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2Cl	BC849CW	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
2CZ	FMMT A70	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 40 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 40...400; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2D	BC849	CDIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 200...800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2D	BC849W	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 200...800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
2D	KST92	SAMS	npn	$V_{CE0} < 300 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2D	MBT A92	TOSH	npn	$V_{CE0} < 300 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2D	MMBT4125	MOT	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 50...150$	SOT23,SOD23	B•E•C
2D	MMBT A92	VISH	npn	$V_{CE0} < 300 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 300 \text{ мВт}; h_{21} > 25; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2D	MMBT A92	MOT	npn	$V_{CE0} < 300 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 300 \text{ мВт}; h_{21} > 25; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2Dp	BC849	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 200...800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2Dt	BC849	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 200...800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2E	FMMT A93	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 200 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 30...150; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2E	KST93	SAMS	npn	$V_{CE0} < 200 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2E	MMBT A93	MOT	npn	$V_{CE0} < 200 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 300 \text{ мВт}; h_{21} > 25; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2F	BC850B	ITT	npn	$V_{CE0} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 200...450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2F	BC850B	CDIL	npn	$V_{CE0} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 200...450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2F	FMMT2907A	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 60 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2F	KST2907A	SAMS	npn	$V_{CE0} < 60 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
2F	MBT2907A	TOSH	npn	$V_{CE0} < 60 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3
2F	MMBT2907A	VISH	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 310 \text{ мВт}; h_{21} > 75; 300; f_T < 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2F	MMBT2907ALT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 100; 300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2F	MMBT2907AWT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 100; 300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	В·Е·С
2F	TMPT2907A	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_{CB0} < 10 \text{ нА}; h_{21} = 100; 300; V_{CE(sat)} < 0.4 \text{ В}; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2F-	BC850BW	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 200; 450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	В·Е·С
2Fp	BC850B	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 200; 450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2FR	2SB792AR	PAN	npn	$V_{CE0} = 185 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 130; 220; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2FR	BC850BR	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 310 \text{ мВт}; h_{21} = 330; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	Е·В·С
2FS	2SB792AS	PAN	npn	$V_{CE0} = 185 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 185; 330; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2Fs	BC850B	INF	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 200; 450; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2F-	BC850BT	INF	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 200; 450; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT416, SC75A	В·Е·С
2Fs	BC850BW	INF	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 200; 450; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	В·Е·С
2Ft	BC850B	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 200; 450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2Ft	BC850BW	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 200; 450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	В·Е·С
2FZ	BC850B	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 200; 450; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2G	BC850C	ITT	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 420; 800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2G	BC850C	CDIL	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 420; 800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2G	BC850C	ITT	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 420; 800; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2G	FMMTA56	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 80 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2G	KST56	SAMS	npn	$V_{CE0} = 80 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2G	MMBT456	VISH	npn	$V_{CE0} = 80 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T < 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2G	MMBT456	MOT	npn	$V_{CE0} = 80 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T < 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2G	TMPT456	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 80 \text{ В}; I_{CB0} < 100 \text{ нА}; h_{21} > 50; V_{CE(sat)} < 0.25 \text{ В}; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2G-	BC850CW	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 420; 800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	В·Е·С
2Gp	BC850C	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 420; 800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2GR	BC850CR	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 310 \text{ мВт}; h_{21} = 600; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	Е·В·С
2Gs	BC850C	INF	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 420; 800; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2Gs	BC850CT	INF	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 420; 800; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT416, SC75A	В·Е·С
2Gt	BC850C	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 420; 800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2Gt	BC850CW	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 420; 800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	В·Е·С
2GT	SOA56	STM	npn	$V_{CE0} = 80 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2H	BC850	CDIL	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 200; 800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2H	BC850W	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 200; 800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	В·Е·С
2H	FMMTA55	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2H	KST55	SAMS	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2H	MMBT455	VISH	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 225 \text{ мВт}; h_{21} = 50; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2H	MMBT455	MOT	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 225 \text{ мВт}; h_{21} = 50; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2H	TMPT455	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_{CB0} < 100 \text{ нА}; h_{21} > 50; V_{CE(sat)} < 0.25 \text{ В}; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2Hp	BC850	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 200; 800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2HT	SOA55	STM	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 625 \text{ мВт}; h_{21} > 100; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2J	MMBT3640LT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 12 \text{ В}; I_C = 80 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 30; 120; f_T > 500 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2K	FMMT4402	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 50; 150; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2K	MMBT8598LT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 225 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2L	FMMT4403	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 100; 300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2L	KST5401	SAMS	npn	$V_{CE0} = 160 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 60; 240; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2L	MMBT5401	VISH	npn	$V_{CE0} = 160 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 60; 240; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2L	MMBT5401	MOT	npn	$V_{CE0} = 150 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 40; 200; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2L	TMPT5401	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 160 \text{ В}; I_{CB0} < 50 \text{ нА}; h_{21} = 60; 240; V_{CE(sat)} < 0.2 \text{ В}; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2m	FMMT5087	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 250; 800; f_T > 40 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2N	MMBT404ALT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 100; 400$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2NO	ZXT11N20DF	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 2.5 \text{ А}; P_D = 625 \text{ мВт}; h_{21} = 300; 900; f_T = 160 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В·Е·С
2NQ	2SD1478Q	PAN	dnnpn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 4000; 10000$	SOT346, SC59	В·Е·С

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
2NR	2SD1478R	PAN	dnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 8000...20000$	SOT346, SC59	B-E-C
20Q	2SD1478AQ	PAN	dnpn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 4000...10000$	SOT346, SC59	B-E-C
2OR	2SD1478AR	PAN	dnpn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 8000...20000$	SOT346, SC59	B-E-C
2P	FMMT2222R	ZETEX	nnpn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 120...360; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2P	KST5086	SAMS	pnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 50 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 150...500; f_T > 40 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2P	MMBT5086	MOT	pnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 50 мА; P_D = 225 мВт; h_{21} = 150...600; f_T > 40 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2P	TMPT5086	ALLEG	pnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_{Cmax} < 50 мА; h_{21} = 150...500; V_{CE(sat)} < 0.3 В; f_T > 40 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2Q	FMMT5209	ZETEX	nnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 50 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 30 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2Q	KST5087	SAMS	pnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 50 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 250...800; f_T > 40 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2Q	MMBT5087	MOT	pnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 50 мА; P_D = 225 мВт; h_{21} = 250...900; f_T > 40 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2Q	TMPT5087	ALLEG	pnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_{Cmax} < 50 мА; h_{21} = 250...800; V_{CE(sat)} < 0.3 В; f_T > 40 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2R	FMMT5210	ZETEX	nnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 50 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 200...600; f_T > 30 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2R	HSMS-8102	HP	shd-2	$V_{BR} = 4 В; V_{f(I_F = 1 мА)} < 0.35 В; C_D < 0.26 пФ; P_D = 14 Ом$	SOT23, SOD23	K1-A2, A1-K2
2T	HT2	ZETEX	nnpn	$V_{CE0} = 90 В; I_C = 100 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} > 25$	SOT23, SOD23	B-E-C
2T	KST4403	SAMS	pnnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2T	MMBT4403	VISH	pnnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 800 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2T	MMBT4403LT1	MOT	pnnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 600 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2T	SO4403	STM	pnnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 600 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2T	TMPT4403	ALLEG	pnnp	$V_{CE0} = 40 В; h_{21} = 100...300; V_{CE(sat)} < 0.4 В; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2U	KST63	SAMS	pnnp	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 2500; f_T > 125 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2U	MMBT463LT1	MOT	dnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 5000; f_T > 125 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2V	KST64	SAMS	pnnp	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2V	MMBT464LT1	MOT	dnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 10000; f_T > 125 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2V4	PZM2.4NB	PHIL	dz	$V_{f(I_{F2} = 5 мА)} = 2.3...2.6 В; Z_{T1}(I_{F2} = 5 мА) < 100 Ом$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
2V7	PZM2.7NB	PHIL	dz	$V_{f(I_{F2} = 5 мА)} = 2.5...2.9 В; Z_{T1}(I_{F2} = 5 мА) < 100 Ом$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
2W	2SC3704	PAN	nnpn	$V_{CE0} = 15 В; I_C = 80 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 50...300; f_T = 6 ГГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2W	2SC3937	PAN	nnpn	$V_{CE0} = 15 В; I_C = 80 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 50...300; f_T = 6 ГГц$	SOT323, SC70	B-E-C
2W	FMMT3905	ZETEX	pnnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 200 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 50...150; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2W	MMBT8599LT1	MOT	pnnp	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2W	TMPT4402	ALLEG	pnnp	$V_{CE0} = 40 В; h_{21} = 50...150; V_{CE(sat)} < 0.4 В; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2X	2SC3707	PAN	nnpn	$V_{CE0} = 10 В; I_C = 10 мА; P_D = 50 мВт; h_{21} = 50...150; f_T = 4 ГГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2X	KST4401	SAMS	nnpn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2X	MMBT4401	VISH	nnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 800 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2X	MMBT4401LT1	MOT	nnpn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2X	SO4401	STM	nnpn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2X	TMPT4401	ALLEG	pnnp	$V_{CE0} = 60 В; I_{Cmax} < 100 мА; h_{21} = 100...300; V_{CE(sat)} < 0.4 В; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2YQ	2SC3757Q	PAN	nnpn	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 300 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 60...120; f_T = 450 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2YQ	2SC3938Q	PAN	nnpn	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 300 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 60...120; f_T = 450 МГц$	SOT23, SC70	B-E-C
2YQ	2SC4691Q	PAN	nnpn	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 100 мА; P_D = 125 мВт; h_{21} = 60...120; f_T = 450 МГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
2YR	2SC3757R	PAN	nnpn	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 300 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 90...200; f_T = 450 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2YR	2SC3938R	PAN	nnpn	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 300 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 90...200; f_T = 450 МГц$	SOT23, SC70	B-E-C
2YR	2SC4691R	PAN	nnpn	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 100 мА; P_D = 125 мВт; h_{21} = 90...200; f_T = 450 МГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
2Z	BAS7004	ZETEX	shd-2	$V_R = 70 В; V_{f(I_F = 1 мА)} < 0.41 В; I_R < 0.2 мкА; C_D < 2.0 пФ$	SOT23, SOD23	A1-K2, K1-A2
2Z	MMBT6520	MOT	pnnp	$V_{CE0} = 350 В; I_C = 500 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 20...200; f_T > 40 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
2Z5	BAS7005	ZETEX	shd-2	$V_R = 70 В; V_{f(I_F = 1 мА)} < 0.41 В; I_R < 0.2 мкА; C_D < 2.0 пФ$	SOT23, SOD23	A1-A2, K1-K2
2Z5	BAS70-05	ZETEX	shd-2	$V_R = 70 В; I_R < 70 мА; V_{f(I_F = 1 мА)} < 410 мВ; C_D < 2 пФ$	SOT23, SOD23	A1-A2, K1-K2
3.0X	02C23.0	TOSH	dz	$V_{f(I_{F2} = 5 мА)} = 2.80...3.20 В; I_{(V_R = 1.0 В)} < 50 мкА; Z_{T1}(I_{F2} = 0.5 мА) < 1000 Ом$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
3.3X	02C23.3	TOSH	dz	$V_{f(I_{F2} = 5 мА)} = 3.10...3.50 В; I_{(V_R = 1.0 В)} < 20 мкА; Z_{T1}(I_{F2} = 0.5 мА) < 1000 Ом$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
3.6X	02C23.6	TOSH	dz	$V_{f(I_{F2} = 5 мА)} = 3.40...3.80 В; I_{(V_R = 1.0 В)} < 10 мкА; Z_{T1}(I_{F2} = 0.5 мА) < 1000 Ом$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
3.9X	02C23.9	TOSH	dz	$V_{f(I_{F2} = 5 мА)} = 3.70...4.10 В; I_{(V_R = 1.0 В)} < 10 мкА; Z_{T1}(I_{F2} = 0.5 мА) < 1000 Ом$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
301	FDV301N	FAIR	DnMOS	$V_{DS} = 25 В; I_D = 220 мА; P_D = 350 мВт; R_{DS(on)} = 5 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
302	FDV302P	FAIR	DpMOS	$V_{DS} = 25 В; I_D = 120 мА; P_D = 350 мВт; R_{DS(on)} = 13 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
303	FDV303N	FAIR	DnMOS	$V_{DS} < 25 \text{ В}; I_D < 680 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 0.45 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
304	FDV304P	FAIR	DpMOS	$V_{DS} < 25 \text{ В}; I_D < 460 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 1.10 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
305	AT30533	HP	npn	$V_{CE(sat)} < 11 \text{ В}; I_C < 8 \text{ мА}; P_D < 100 \text{ мВт}; h_{FE} > 70...300; f_T > 10 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
30p	BF861C	PHIL	nFET	$V_{DS} < 25 \text{ В}; I_{DSS} < 25 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; g_m > 20 \text{ мС}$	SOT23, SOD23	S-D-G
30f	BF861C	PHIL	nFET	$V_{DS} < 25 \text{ В}; I_{DSS} < 25 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; g_m > 20 \text{ мС}$	SOT23, SOD23	S-D-G
30V	PZM30NB	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} < 2 \text{ мА}) < 28...32.0 \text{ В}; Z_{T1}(I_{Z1} < 2 \text{ мА}) < 40 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
30W	BF861C	PHIL	nFET	$V_{DS} < 25 \text{ В}; I_{DSS} < 25 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; g_m > 20 \text{ мС}$	SOT23, SOD23	S-D-G
30X	02C230	TOSH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} < 2 \text{ мА}) < 28...32.00 \text{ В}; I_L(V_{R1} < 23 \text{ В}) < 0.5 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_{Z1} < 0.5 \text{ мА}) < 250 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
31	MMBD1402	ON	d	$V_R < 175 \text{ В}; I_F < 600 \text{ мА}; V_{F1}(I_F < 200 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ пФ}$	SOT23, SOD23	n.c.-A-K
310	AT31033	HP	npn	$V_{CE(sat)} < 11 \text{ В}; I_C < 16 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 70...300; f_T > 10 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
31p	BFR505	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} < 20 \text{ В}; I_C < 18 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 60...250; f_T > 9 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
311	BFR505	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} < 20 \text{ В}; I_C < 18 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 60...250; f_T > 9 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
31W	BFR505	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} < 20 \text{ В}; I_C < 18 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 60...250; f_T > 9 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
32	MMBD1403	FAIR	d-2	$V_R < 175 \text{ В}; I_F < 600 \text{ мА}; V_{F1}(I_F < 200 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ пФ}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1,A2
32	MMBD1403	ON	d-2	$V_R < 175 \text{ В}; I_F < 600 \text{ мА}; V_{F1}(I_F < 200 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ пФ}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1,A2
320	AT32033	HP	npn	$V_{CE(sat)} < 11 \text{ В}; I_C < 32 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 70...300; f_T > 10 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
32p	BFR520	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} < 20 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; P_D < 300 \text{ мВт}; h_{21} > 60...250; f_T > 9 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
32t	BFR520	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} < 20 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; P_D < 300 \text{ мВт}; h_{21} > 60...250; f_T > 9 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
32W	BFR520	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} < 20 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; P_D < 300 \text{ мВт}; h_{21} > 60...250; f_T > 9 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
33	DTA143XE	ROHM	Dpnp	$V_{CE(sat)} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 30; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 < 4.7/10 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
33	DTA143XKA	ROHM	Dpnp	$V_{CE(sat)} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 30; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 < 4.7/10 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
33	DTA143XUA	ROHM	Dpnp	$V_{CE(sat)} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 30; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 < 4.7/10 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
33	MMBD1404	FAIR	d-2	$V_R < 175 \text{ В}; I_F < 600 \text{ мА}; V_{F1}(I_F < 200 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ пФ}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1,K2
33	MMBD1404	ON	d-2	$V_R < 175 \text{ В}; I_F < 600 \text{ мА}; V_{F1}(I_F < 200 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ пФ}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1,K2
33	PDTC114YE	PHIL	Dpnp	$V_{CE(sat)} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 100; 10 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
331	NDS331N	FAIR	nMOS	$V_{DS} < 20 \text{ В}; I_D < 1.3 \text{ А}; P_D < 500 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 0.4 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
332	NDS332P	FAIR	pMOS	$V_{DS} < 20 \text{ В}; I_D < 1 \text{ А}; P_D < 500 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 0.74 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
335	NDS335N	FAIR	nMOS	$V_{DS} < 20 \text{ В}; I_D < 1.7 \text{ А}; P_D < 500 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 0.25 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
336	NDS336P	FAIR	pMOS	$V_{DS} < 20 \text{ В}; I_D < 1.2 \text{ А}; P_D < 500 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 0.49 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
337	NDS337N	FAIR	nMOS	$V_{DS} < 20 \text{ В}; I_D < 2.5 \text{ А}; P_D < 500 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	G-S-D
338	NDS338P	FAIR	pMOS	$V_{DS} < 20 \text{ В}; I_D < 1.6 \text{ А}; P_D < 500 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	G-S-D
33A	MMBZ33VAL	ON	dz-2	$V_{Z1}(I_{Z1} < 1 \text{ мА}) < 31.35...34.65 \text{ В}; Z_{T1}(I_{Z1} < 10 \text{ мА}) < 0.9 \text{ В}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1,A2
33p	BFR540	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} < 20 \text{ В}; I_C < 120 \text{ мА}; P_D < 500 \text{ мВт}; h_{21} > 100...250; f_T > 9 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
33t	BFR540	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} < 20 \text{ В}; I_C < 120 \text{ мА}; P_D < 500 \text{ мВт}; h_{21} > 100...250; f_T > 9 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
33V	PZM33NB	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} < 2 \text{ мА}) < 31.0...35.0 \text{ В}; Z_{T1}(I_{Z1} < 2 \text{ мА}) < 40 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
33W	BFR540	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} < 20 \text{ В}; I_C < 120 \text{ мА}; P_D < 500 \text{ мВт}; h_{21} > 100...250; f_T > 9 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
33X	02C233	TOSH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} < 2 \text{ мА}) < 31.00...35.00 \text{ В}; I_L(V_{R1} < 25 \text{ В}) < 0.5 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_{Z1} < 0.5 \text{ мА}) < 250 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
34	MMBD1405	FAIR	d-2	$V_R < 175 \text{ В}; I_F < 600 \text{ мА}; V_{F1}(I_F < 200 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ пФ}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1,A2
34	MMBD1405	ON	d-2	$V_R < 175 \text{ В}; I_F < 600 \text{ мА}; V_{F1}(I_F < 200 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ пФ}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1,A2
34	PDTC143XE	PHIL	Dpnp	$V_{CE(sat)} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; 4.7 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
340	FDV340P	FAIR	DpMOS	$V_{DS} < 20 \text{ В}; I_D < 70 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	G-S-D
35	DTA124XE	ROHM	Dnpn	$V_{CE(sat)} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 68; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 < 22/47 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
35	DTA124XKA	ROHM	Dnpn	$V_{CE(sat)} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 68; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 < 22/47 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
35	DTA124XUA	ROHM	Dnpn	$V_{CE(sat)} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 68; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 < 22/47 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
35	PDTA143XE	PHIL	Dpnp	$V_{CE(sat)} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; 4.7 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
351	NDS351N	FAIR	nMOS	$V_{DS} < 30 \text{ В}; I_D < 1.1 \text{ А}; P_D < 500 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	G-S-D
352	NDS352P	FAIR	pMOS	$V_{DS} < 20 \text{ В}; I_D < 0.5 \text{ А}; P_D < 500 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	G-S-D

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
355	NDS355N	FAIR	nMOS	$V_{DS} < 30 В; I_D > 1.6 А; P_D < 500 мВт$	SOT23, SOD23	G•S•D
356	NDS356P	FAIR	pMOS	$V_{DS} < 20 В; I_D > 1.1 А; P_D < 500 мВт$	SOT23, SOD23	G•S•D
357	NDS357N	FAIR	nMOS	$V_{DS} < 30 В; I_D > 2.5 А; P_D < 500 мВт$	SOT23, SOD23	G•S•D
358	NDS358P	FAIR	pMOS	$V_{DS} < 30 В; I_D > 1.6 А; P_D < 500 мВт$	SOT23, SOD23	G•S•D
36	PDTA114YE	PHIL	Dnnp	$V_{CE} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 100; 10 кОм/47 кОм$	SOT416, SC75A	B•E•C
36	PDTC124EEF	PHIL	Dnnp	$V_{CE} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{21} > 60; 22 кОм/22 кОм$	SOT490, SC89	B•E•C
360	FDN360P	FAIR	DpMOS	$V_{DS} < 30 В; I_D > 2 А; P_D < 500 мВт; R_{DS(on)} < 0.08 Ом$	SOT23, SOD23	G•S•D
36V	PZM36NB	PHIL	dz	$V_{ZT} (I_{ZT} = 2 мА) < 34.0...38.0 В; Z_{T1} (I_{ZT} = 2 мА) < 60 Ом$	SOT346, SC59	A•n.c.•K
36X	Q2C236	TOSH	dz	$V_{ZT} (I_{ZT} = 2 мА) < 34.00...38.00 В; I_{ZT} (V_{ZT} = 27 В) < 0.5 мА; Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 250 Ом$	SOT346, SC59	A•n.c.•K
37	PDTA114YEF	PHIL	Dnnp	$V_{CE} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 100; 10 кОм/47 кОм$	SOT490, SC89	B•E•C
37	PDTA143ZE	PHIL	Dnnp	$V_{CE} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{21} > 100; 4.7 кОм/47 кОм$	SOT416, SC75A	B•E•C
38	PDTC143ZE	PHIL	Dnnp	$V_{CE} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{21} > 100; 4.7 кОм/47 кОм$	SOT416, SC75A	B•E•C
38p	PMBFJ108	PHIL	nFET	$V_{DS} < 25 В; I_{DSS} > 80 мА; P_D < 250 мВт; R_{DS(on)} < 8 Ом$	SOT23, SOD23	D•S•G
38t	PMBFJ108	PHIL	nFET	$V_{DS} < 25 В; I_{DSS} > 80 мА; P_D < 250 мВт; R_{DS(on)} < 8 Ом$	SOT23, SOD23	D•S•G
38W	PMBFJ108	PHIL	nFET	$V_{DS} < 25 В; I_{DSS} > 80 мА; P_D < 250 мВт; R_{DS(on)} < 8 Ом$	SOT23, SOD23	D•S•G
39p	PMBFJ109	PHIL	nFET	$V_{DS} < 25 В; I_{DSS} > 40 мА; P_D < 250 мВт; R_{DS(on)} < 12 Ом$	SOT23, SOD23	D•S•G
39t	PMBFJ109	PHIL	nFET	$V_{DS} < 25 В; I_{DSS} > 40 мА; P_D < 250 мВт; R_{DS(on)} < 12 Ом$	SOT23, SOD23	D•S•G
39V	PZM39NB	PHIL	dz	$V_{ZT} (I_{ZT} = 2 мА) < 37.0...41.0 В; Z_{T1} (I_{ZT} = 2 мА) < 75 Ом$	SOT346, SC59	A•n.c.•K
39W	PMBFJ109	PHIL	nFET	$V_{DS} < 25 В; I_{DSS} > 40 мА; P_D < 250 мВт; R_{DS(on)} < 12 Ом$	SOT23, SOD23	D•S•G
39X	Q2C239	TOSH	dz	$V_{ZT} (I_{ZT} = 2 мА) < 37.00...41.00 В; I_{ZT} (V_{ZT} = 30 В) < 0.5 мА; Z_{T1} (I_{ZT} = 0.5 мА) < 250 Ом$	SOT346, SC59	A•n.c.•K
3A	BC856A	CDIL	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} > 110...220; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3A	BC856A	TOSH	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} > 125...250; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3A	BC856A	VISH	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} > 110...220; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3A	BC856A	ZETEX	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 330 мВт; h_{21} > 125...250; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3A	BC856A	DIODS	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 300 мВт; h_{21} > 125...250; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3A	BC856A	ITT	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 330 мВт; h_{21} > 125...250; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3A	BC856AF	PHIL	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{21} > 125...250; f_T > 100 МГц$	SOT490, SC89	B•E•C
3A	BC856ALT1	MOT	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 300 мВт; h_{21} > 125...250; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3A	BC856AT	PHIL	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} > 125...250; f_T > 100 МГц$	SOT416, SC75A	B•E•C
3A	KST24	SAMS	npn	$V_{CE} < 40 В; I_C < 100 мА; P_D < 350 мВт; h_{21} > 30; f_T > 620 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3A	MMBTH24	MOT	npn	$V_{CE} < 40 В; I_C < 50 мА; P_D < 300 мВт; h_{21} > 30; f_T > 400 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3A-	BC856AW	PHIL	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 125...250; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
3A0	PZM3.0NB2A	PHIL	dz-2	$V_{ZT} (I_{ZT} = 5 мА) < 2.95...3.2 В; Z_{T1} (I_{ZT} = 5 мА) < 95 Ом$	SOT346, SC59	K1•K2•A1•A2
3A3	PZM3.3NB2A	PHIL	dz-2	$V_{ZT} (I_{ZT} = 5 мА) < 3.25...3.5 В; Z_{T1} (I_{ZT} = 5 мА) < 95 Ом$	SOT346, SC59	K1•K2•A1•A2
3A6	PZM3.6NB2A	PHIL	dz-2	$V_{ZT} (I_{ZT} = 5 мА) < 3.55...3.8 В; Z_{T1} (I_{ZT} = 5 мА) < 90 Ом$	SOT346, SC59	K1•K2•A1•A2
3A9	PZM3.9NB2A	PHIL	dz-2	$V_{ZT} (I_{ZT} = 5 мА) < 3.87...4.1 В; Z_{T1} (I_{ZT} = 5 мА) < 90 Ом$	SOT346, SC59	K1•K2•A1•A2
3Ap	BC856A	PHIL	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{21} > 125...250; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3Ar	BC856AR	PHIL	pnp	$V_{CE} < 65 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 125; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3AS	BC856A	INF	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 330 мВт; h_{21} > 125...250; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3As	BC856AT	INF	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{21} > 125...250; f_T > 250 МГц$	SOT416, SC75A	B•E•C
3As	BC856AW	INF	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{21} > 125...250; f_T > 250 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
3At	BC856A	PHIL	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{21} > 125...250; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3At	BC856AW	PHIL	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 125...250; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
3B	BC856B	CDIL	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} > 200...450; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3B	BC856B	TOSH	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} > 220...475; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3B	BC856B	DIODS	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 300 мВт; h_{21} > 220...475; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3B	BC856B	VISH	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} > 200...450; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3B	BC856B	ITT	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} > 200...450; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
3B	BC856BF	PHIL	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{21} > 220...475; f_T > 100 МГц$	SOT490, SC89	B•E•C
3B	BC856BLT1	MOT	pnp	$V_{CE} < 80 В; I_C < 100 мА; P_D < 300 мВт; h_{21} > 220...475; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3
3B	BC856BT	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 80$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 100$ МГц	SOT416, SC75A	В•Е•С
3B	FMMT918	ZETEX	npn	$V_{CE0} > 30$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 330$ мВт; $h_{21} > 20$; $f_T > 600$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3B	TMPT918	ALLEG	npn	$V_{CE0} > 30$ В; $I_{C85} > 10$ мА; $h_{21} > 20$; $V_{CE(sat)} < 0.4$ В; $f_T > 600$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3B-	BC856BW	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 80$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 200$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
3Bp	BC856B	PHIL	npn	$V_{CE0} > 80$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3BR	BC856BR	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 65$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 200$ мВт; $h_{21} > 475$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	Е•В•С
3Bs	BC856B	INF	pnp	$V_{CE0} > 80$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 330$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3Bs	BC856BT	INF	pnp	$V_{CE0} > 80$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 250$ МГц	SOT416, SC75A	В•Е•С
3Bs	BC856BW	INF	pnp	$V_{CE0} > 80$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 250$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
3Bt	BC856B	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 80$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3Bt	BC856BW	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 80$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 200$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
3C	FMMT2A20R	ZETEX	npn	$V_{CE0} > 40$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 330$ мВт; $h_{21} > 40...400$; $f_T > 125$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3D	BC856	CDIL	npn	$V_{CE0} > 80$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 125...800$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3D	MMBTH11T1	MOT	npn	$V_{CE0} > 20$ В; $P_D > 300$ мВт; $h_{21} > 60$; $f_T > 650$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3D-	BC856W	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 80$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 200$ мВт; $h_{21} > 125...800$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
3Dp	BC856	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 80$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 125...800$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3Dt	BC856	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 80$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 125...800$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3Dt	BC856W	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 80$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 200$ мВт; $h_{21} > 125...800$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
3E	BC857A	CDIL	npn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 310$ мВт; $h_{21} > 110...220$; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3E	BC857A	TOSH	npn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 125...250$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3E	BC857A	VISH	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 310$ мВт; $h_{21} > 110...220$; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3E	BC857A	DIODS	npn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 300$ мВт; $h_{21} > 110...220$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3E	BC857AF	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 125...250$; $f_T > 100$ МГц	SOT490, SC89	В•Е•С
3E	BC857ALT1	MOT	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 300$ мВт; $h_{21} > 125...250$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3E	BC857AT	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 125...250$; $f_T > 100$ МГц	SOT416, SC75A	В•Е•С
3E	FMMT4A2	ZETEX	npn	$V_{CE0} > 300$ В; $I_C > 200$ мА; $P_D > 330$ мВт; $h_{21} > 40$; $f_T > 50$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3E	KST10	SAMS	npn	$V_{CE0} > 30$ В; $P_D > 350$ мВт; $h_{21} > 60$; $f_T > 650$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3E	MMBTH10	MOT	npn	$V_{CE0} > 30$ В; $P_D > 300$ мВт; $h_{21} > 60$; $f_T > 650$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3E-	BC857AW	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 200$ мВт; $h_{21} > 125...250$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
3EM	MMBTH10LT1	MOT	npn	$V_{CE0} > 30$ В; $P_D > 300$ мВт; $h_{21} > 60$; $f_T > 650$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3Ep	BC857A	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 125...250$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3ER	BC857AR	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 45$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 220$; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	Е•В•С
3Es	BC857A	INF	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 330$ мВт; $h_{21} > 125...250$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3Es	BC857AW	INF	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 125...250$; $f_T > 250$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
3Et	BC857A	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 125...250$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3Et	BC857AW	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 200$ мВт; $h_{21} > 125...250$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
3EZ	FMMTH10	ZETEX	npn	$V_{CE0} > 30$ В; $I_C > 25$ мА; $P_D > 330$ мВт; $h_{21} > 60$; $f_T > 650$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3F	BC857B	CDIL	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 310$ мВт; $h_{21} > 200...450$; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3F	BC857B	DIODS	npn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 300$ мВт; $h_{21} > 200...450$; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3F	BC857B	TOSH	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3F	BC857B	VISH	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 310$ мВт; $h_{21} > 200...450$; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3F	BC857B	ZETEX	npn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 330$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3F	BC857BF	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 100$ МГц	SOT490, SC89	В•Е•С
3F	BC857BLT1	MOT	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 300$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3F	BC857BT	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 100$ МГц	SOT416, SC75A	В•Е•С
3F-	BC857BW	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 200$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
3Fp	BC857B	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3Fr	BC857BR	PHIL	pnp	$V_{CE0} > 45$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 200$ мВт; $h_{21} > 475$; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	Е•В•С
3Fs	BC857B	INF	pnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 330$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3Fs	BC857B	SIEM	npn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 330$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С
3Fs	BC857BW	SIEM	pnnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 250$ МГц	SOT323, SC70	В•Е•С
3Ft	BC857B	PHIL	pnnp	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C > 100$ мА; $P_D > 250$ мВт; $h_{21} > 220...475$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В•Е•С

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
3F1	BC857BW	PHL	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=220...475; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
3G	BC857C	CDIL	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3G	BC857C	TOSH	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3G	BC857C	DIODS	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3G	BC857C	VISH	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3G	BC857C	ZETEX	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3G	BC857CF	PHIL	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 100 МГц$	SOT490, SC89	B-E-C
3G	BC857CT	PHIL	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 100 МГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
3G	BC857CT	DIODS	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 150 МГц$	SOT523	B-E-C
3G	MMBTH11	FAIR	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=50 мА; P_D=3225 мВт; h_{21} > 60; f_T < 650 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3G-	BC857CW	PHIL	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
3Gr	BC857C	PHIL	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3Gr	BC857CR	PHIL	rnp	$V_{CBO}=45 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=800; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	E-B-C
3GS	BC857C	INF	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3Gs	BC857CW	INF	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 50 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
3Gt	BC857C	PHIL	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3Gt	BC857CW	PHIL	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
3H	BC857	CDIL	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...800; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3H	BC857W	PHIL	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...800; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
3H	MMBTH30	NS	rnp	$V_{CBO}=20 В; I_C=50 мА; P_D=350 мВт; h_{21} > 200; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3Hr	BC857	PHIL	rnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...800; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3J	BC858A	CDIL	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=110...220; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3J	BC858A	VISH	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=110...220; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3J	BC858A	ZETEX	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=125...250; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3J	BC858A	DIODS	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=125...250; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3J	BC858AF	PHIL	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T > 100 МГц$	SOT490, SC89	B-E-C
3J	BC858ALT1	MOT	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=125...250; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3J	BC858AW	PHIL	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=125...250; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
3J	MMBTH69	MOT	rnp	$V_{CBO}=15 В; P_D=300 мВт; h_{21}=30...300; f_T > 2000 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3J	RB706F-40	ROHM	shd-2	$V_A < 40 В; I_F < 30 мА; V_{E(I_F=1 мА)} < 370 мВ; C_{E2}=2 нФ$	SOT323, SC70	A1-K1, A2-K2
3Jp	BC858A	PHIL	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3JR	BC858AR	PHIL	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	E-B-C
3Js	BC858A	INF	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=125...250; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3Js	BC858AW	SIEM	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T > 250 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
3Jt	BC858A	PHIL	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=125...250; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3K	BC858B	CDIL	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=200...450; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3K	BC858B	TOSH	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=220...475; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3K	BC858B	DIODS	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=220...475; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3K	BC858B	VISH	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=200...450; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3K	BC858B	ZETEX	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=220...475; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3K	BC858BF	PHIL	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T > 100 МГц$	SOT490, SC89	B-E-C
3K	BC858BLT1	MOT	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=300 мВт; h_{21}=220...475; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3K	BC858BW	PHIL	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=220...475; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
3KR	BC858B	PHIL	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3KR	BC858BR	PHIL	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21}=475; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	E-B-C
3Ks	BC858B	SIEM	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=220...475; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3Ks	BC858BW	SIEM	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T > 250 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
3Kt	BC858B	PHIL	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=250 мВт; h_{21}=220...475; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3L	BC858C	CDIL	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3L	BC858C	TOSH	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3L	BC858C	VISH	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=310 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
3L	BC858C	ZETEX	rnp	$V_{CBO}=30 В; I_C=100 мА; P_D=330 мВт; h_{21}=420...800; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3
3L	BC858C	DIODS	pnp	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 300$ мВт; $h_{21} < 420...800$; $f_T > 100$ МГц	SOT490, SOD23	B-E-C
3L	BC858CF	PHIL	pnp	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 250$ мВт; $h_{21} < 420...800$; $f_T > 100$ МГц	SOT490, SC89	B-E-C
3L	BC858CLT1	MOT	pnp	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 300$ мВт; $h_{21} < 420...800$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
3L	BC858CW	PHIL	pnp	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 200$ мВт; $h_{21} < 420...800$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	B-E-C
3Lp	BC858C	PHIL	pnp	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 250$ мВт; $h_{21} < 420...800$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
3LR	BC858CR	PHIL	pnp	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 250$ мВт; $h_{21} < 800$; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	E-B-C
3Ls	BC858C	SIEM	pnp	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} < 420...800$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
3Ls	BC858CW	SIEM	pnp	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 250$ мВт; $h_{21} < 420...800$; $f_T > 250$ МГц	SOT323, SC70	B-E-C
3Lt	BC858C	PHIL	pnp	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 250$ мВт; $h_{21} < 420...800$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
3M	ZSC4808	PAN	npn	$V_{CBO} > 15$ В; $I_C < 80$ мА; $P_D < 125$ мВт; $h_{21} < 50...300$; $f_T > 5$ ГГц	SOT416, SC75A	B-E-C
3M	ZSC4835	PAN	npn	$V_{CBO} > 15$ В; $I_C < 80$ мА; $P_D < 150$ мВт; $h_{21} < 50...200$; $f_T > 5$ ГГц	SOT323, SC70	B-E-C
3M	BC858	CDIL	pnp	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 250$ мВт; $h_{21} < 125...800$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
3M	BC858W	PHIL	pnp	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 200$ мВт; $h_{21} < 125...800$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SC70	B-E-C
3m	FMMT5087R	ZETEX	npn	$V_{CBO} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} < 200...600$; $f_T > 40$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
3Mp	BC858	PHIL	pnp	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 250$ мВт; $h_{21} < 125...800$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
3Mt	BC858	PHIL	pnp	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 250$ мВт; $h_{21} < 125...800$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
3N	2SK620	PAN	nMOS	$V_{DS} > 50$ В; $I_D < 100$ мА; $P_D < 150$ мВт; $R_{DS(on)} < 50$ Ом	SOT346, SC59	G-S-D
3N	2SK664	PAN	nMOS	$V_{DS} > 50$ В; $I_D < 100$ мА; $P_D < 150$ мВт; $R_{DS(on)} < 50$ Ом	SOT323, SC70	G-S-D
3N	MMBT3906	VISH	npn	$V_{CBO} > 40$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 200$ мВт; $h_{21} < 100...300$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
3N	MMBT4402	NS	pnp	$V_{CBO} > 40$ В; $I_C < 500$ мА; $P_D < 350$ мВт; $h_{21} > 30$; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
3O	2SK621	PAN	nMOS	$V_{DS} > 20$ В; $I_D < 100$ мА; $P_D < 150$ мВт; $R_{DS(on)} < 50$ Ом	SOT346, SC59	G-S-D
3O	2SK665	PAN	nMOS	$V_{DS} > 20$ В; $I_D < 100$ мА; $P_D < 150$ мВт; $R_{DS(on)} < 50$ Ом	SOT323, SC70	G-S-D
3P	FMMT2222AR	ZETEX	npn	$V_{CBO} > 75$ В; $I_C < 600$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} < 120...360$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
3P	FMT2222AR	ZETEX	npn	$V_{CBO} > 75$ В; $I_C < 800$ мА; $P_D < 500$ мВт; $h_{21} > 30$	SOT23, SOD23	E-B-C
3R	MMBT5571	NS	pnp	$f_T < 850$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
3R	PDTA124EEF	PHIL	Dnpn	$V_{CBO} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 250$ мВт; $h_{21} > 60$; 22 кОм/22 кОм	SOT490, SC89	B-E-C
3S	ZSC4805	PAN	npn	$V_{CBO} > 15$ В; $I_C < 65$ мА; $P_D < 150$ мВт; $h_{21} < 50...300$; $f_T > 7$ ГГц	SOT323, SC70	B-E-C
3S	MMBT5551	ON	npn	$V_{CBO} > 180$ В; $I_C < 200$ мА; $P_D < 350$ мВт; $h_{21} < 80...250$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
3S	MMBT5551	VISH	npn	$V_{CBO} > 180$ В; $I_C < 200$ мА; $P_D < 350$ мВт; $h_{21} < 80...250$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
3S	MMBT5551	NS	npn	$V_{CBO} > 160$ В; $I_C < 600$ мА; $P_D < 300$ мВт; $h_{21} < 80...250$	SOT23, SOD23	B-E-C
3T	HT3	ZETEX	pnp	$V_{CBO} > 90$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} > 30$	SOT23, SOD23	B-E-C
3U	ZSC3967U	PAN	npn	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 20$ мА; $P_D < 200$ мВт; $h_{21} < 40...200$; $f_T > 1.5$ ГГц	SOT23, SOD23	B-E-C
3V	BC857AT	DIODS	pnp	$V_{CBO} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 300$ мВт; $h_{21} < 125...250$; $f_T > 100$ МГц	SOT523	B-E-C
3V0	PZM3.0NB	PHIL	dz	$V_{ZT} (I_{ZT} = 5$ мА) $> 2.8...3.2$ В; $Z_{T1}(I_{ZT} = 5$ мА) < 95 Ом	SOT346, SC59	A-n.c.-K
3V3	PZM3.3NB	PHIL	dz	$V_{ZT} (I_{ZT} = 5$ мА) $> 3.1...3.5$ В; $Z_{T1}(I_{ZT} = 5$ мА) < 95 Ом	SOT346, SC59	A-n.c.-K
3V6	PZM3.6NB	PHIL	dz	$V_{ZT} (I_{ZT} = 5$ мА) $> 3.4...3.8$ В; $Z_{T1}(I_{ZT} = 5$ мА) < 90 Ом	SOT346, SC59	A-n.c.-K
3V9	PZM3.9NB	PHIL	dz	$V_{ZT} (I_{ZT} = 5$ мА) $> 3.7...4.1$ В; $Z_{T1}(I_{ZT} = 5$ мА) < 90 Ом	SOT346, SC59	A-n.c.-K
3W	BC857BT	DIODS	pnp	$V_{CBO} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} < 220...475$; $f_T > 150$ МГц	SOT523	B-E-C
3W	FMMTA12	ZETEX	npn	$V_{CBO} > 20$ В; $I_C < 300$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} > 20000$	SOT23, SOD23	B-E-C
4.3X	02C24.3	TOSH	dz	$V_{ZT} (I_{ZT} = 5$ мА) $> 4.00...4.50$ В; $I_N (V_N = 1.0$ В) < 5 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 0.5$ мА) < 1000 Ом	SOT346, SC59	A-n.c.-K
4.7X	02C24.7	TOSH	dz	$V_{ZT} (I_{ZT} = 5$ мА) $> 4.40...4.90$ В; $I_N (V_N = 1.0$ В) < 5 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 0.5$ мА) < 1000 Ом	SOT346, SC59	A-n.c.-K
40p	PMBFJ110	PHIL	nFET	$V_{DS} > 25$ В; $I_{DSS} > 10$ мА; $P_D < 250$ мВт; $R_{DS(on)} < 18$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G
40t	PMBFJ110	PHIL	nFET	$V_{DS} > 25$ В; $I_{DSS} > 10$ мА; $P_D < 250$ мВт; $R_{DS(on)} < 18$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G
40W	PMBFJ110	PHIL	nFET	$V_{DS} > 25$ В; $I_{DSS} > 10$ мА; $P_D < 250$ мВт; $R_{DS(on)} < 18$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G
41	PDTA143XEF	PHIL	Dnpn	$V_{CBO} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 250$ мВт; $h_{21} > 50$; 4.7 кОм/10 кОм	SOT490, SC89	B-E-C
413	FMMT413	ZETEX	npn	$V_{CBO} > 150$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} > 50$; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
415	FMMT415	ZETEX	npn	$V_{CBO} > 260$ В; $I_C < 500$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} > 25$; $f_T > 40$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
417	FMMT417	ZETEX	npn	$V_{CBO} > 320$ В; $I_C < 500$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} > 25$; $f_T > 40$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
41A	FMMT491A	ZETEX	npn	$V_{CBO} > 40$ В; $I_C < 1000$ мА; $P_D < 500$ мВт; $h_{21} < 300...900$; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
41p	PMBFJ111	PHIL	nFET	$V_{DS} > 40$ В; $I_{DSS} > 20$ мА; $P_D < 300$ мВт; $R_{DS(on)} < 30$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G
41t	PMBFJ111	PHIL	nFET	$V_{DS} > 40$ В; $I_{DSS} > 20$ мА; $P_D < 300$ мВт; $R_{DS(on)} < 30$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G
41W	PMBFJ111	PHIL	nFET	$V_{DS} > 40$ В; $I_{DSS} > 20$ мА; $P_D < 300$ мВт; $R_{DS(on)} < 30$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G

**SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3**

**VMT3
VMD3**



**SOT416
SOT523**

**SOT323
SOT346**

**SOT23-3
SOD23-3**



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
42p	BAT54AW	PHIL	shd-2	$V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 320 мВ; C_D < 10 пФ; I_{TERR} < 5 нС$	SOT323, SC70	K1-K2; A2, A1
42p	PMBFJ112	PHIL	nFET	$V_{DS} < 40 В; I_{DSS} > 5 мА; P_D < 300 мВт; R_{\theta(Sj)} < 50 Ом$	SOT23, SOD23	D-S-G
42i	PMBFJ112	PHIL	nFET	$V_{DS} < 40 В; I_{DSS} > 5 мА; P_D < 300 мВт; R_{\theta(Sj)} < 50 Ом$	SOT23, SOD23	D-S-G
42W	PMBFJ112	PHIL	nFET	$V_{DS} < 40 В; I_{DSS} > 5 мА; P_D < 300 мВт; R_{\theta(Sj)} < 50 Ом$	SOT23, SOD23	D-S-G
43	BAS40	VISH	shd	$V_R < 40 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1.0 В; I_S < 0.2 мкА; C_D < 5.0 пФ; I_{TERR} < 5 нС$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
43	BAS40	DIOT	shd	$V_R < 40 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1.0 В; I_S < 0.2 мкА; C_D < 5.0 пФ; I_{TERR} < 5 нС$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
43	BAS40	MCS	shd	$V_R < 40 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1.0 В; I_S < 0.2 мкА; C_D < 5.0 пФ; I_{TERR} < 5 нС$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
43	BAS40	TSC	shd	$V_R < 40 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1.0 В; I_S < 0.2 мкА; C_D < 5.0 пФ; I_{TERR} < 5 нС$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
43	BAS40	GS	shd	$V_R < 40 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1.0 В; I_S < 0.2 мкА; C_D < 5.0 пФ; I_{TERR} < 5 нС$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
43	BAT54CW	PHIL	shd-2	$V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 320 мВ; C_D < 10 пФ; I_{TERR} < 5 нС$	SOT323, SC70	A1-A2-K1, K2
43	DTC143XE	ROHM	Dnprn	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{FE1} > 30; f_T > 250 МГц; R_{11}/R_{22} = 4,7/10 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
43	DTC143XKA	ROHM	Dnprn	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{FE1} > 30; f_T > 250 МГц; R_{11}/R_{22} = 4,7/10 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
43	DTC143XUA	ROHM	Dnprn	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{FE1} > 30; f_T > 250 МГц; R_{11}/R_{22} = 4,7/10 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
43p	BAS40	PHIL	shd	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 380 мВ; C_D < 5 пФ$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
43s	BAS40	INF	shd	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5 пФ$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
43s	BAS40	SIEM	shd	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1.0 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5.0 пФ$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
43V	PZM43NB	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 2 мА) < 40...46.0 В; Z_{T1}(I_{Z1} = 2 мА) < 80 Ом$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
43X	Q2C243	TOSH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 2 мА) < 40...45.00 В; I_{Z1}(V_R = 33 В) < 0.5 мкА$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
44	BAS4004	VISH	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1.0 В; I_S < 0.2 мкА; C_D < 5.0 пФ; I_{TERR} < 5 нС$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
44	BAS40-04	DIOT	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5 пФ; I_{TERR} < 5 нС$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
44	BAS40-04	MCS	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5 пФ; I_{TERR} < 5 нС$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
44	BAS40-04	TSC	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5 пФ; I_{TERR} < 5 нС$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
44	BAS40-04	GS	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5 пФ; I_{TERR} < 5 нС$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
44	BAT54SW	PHIL	shd-2	$V_R < 30 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 320 мВ; C_D < 10 пФ; I_{TERR} < 5 нС$	SOT323, SC70	A1-K2-K1, A2
449	FMMT449	ZETEX	nprn	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_C < 1000 мА; P_D < 500 мВт; h_{FE1} > 100...300; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
44p	BAS4004	PHIL	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 380 мВ; C_D < 5 пФ$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
44s	BAS4004	SIEM	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1.0 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5.0 пФ$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
44s	BAS40-04	INF	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5 пФ$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
44s	BAS40-04	INF	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5 пФ$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
44s	BAS4004W	SIEM	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5.0 пФ$	SOT323, SC70	A1-K2-K1, A2
44s	BAS40-04W	INF	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5 пФ$	SOT323, SC70	A1-K2-K1, A2
45	BAS4005	VISH	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 200 мА; P_D < 200 мВт; I_{TERR} < 5 нС$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
45	DTC124XE	ROHM	Dnprn	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{FE1} > 68; f_T > 250 МГц; R_{11}/R_{22} = 22/47 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
45	DTC124XKA	ROHM	Dnprn	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{FE1} > 68; f_T > 250 МГц; R_{11}/R_{22} = 22/47 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
45	DTC124XUA	ROHM	Dnprn	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{FE1} > 68; f_T > 250 МГц; R_{11}/R_{22} = 22/47 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
451	FMMT451	ZETEX	nprn	$V_{CE(sat)} < 80 В; I_C < 1000 мА; P_D < 500 мВт; h_{FE1} > 50...150; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
455	FMMT455	ZETEX	nprn	$V_{CE(sat)} < 160 В; I_C < 1000 мА; P_D < 500 мВт; h_{FE1} > 100...300; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
458	FMMT458	ZETEX	nprn	$V_{CE(sat)} < 400 В; I_C < 225 мА; P_D < 500 мВт; h_{FE1} > 100...300; f_T > 50 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
459	TMPD459	ALLEG	di	$I_S < 500 мА; V_{RRM} > 200 В; V_{F1}(I_F = 3 мА) < 1.0 В; I_S < 25 нА; C_D < 6.0 пФ$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
45p	BAS4005	PHIL	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 380 мВ; C_D < 5 пФ$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, K2
45s	BAS4005	SIEM	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1.0 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5.0 пФ$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, A2
45s	BAS40-05	INF	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5 пФ$	SOT23, SOD23	A1-A2-K2, K1
45s	BAS4005W	SIEM	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5.0 пФ$	SOT323, SC70	A1-K2-K1, A2
45s	BAS40-05W	INF	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5 пФ$	SOT323, SC70	A1-A2-K2, K1
46	BAS4006	VISH	shd	$V_R < 40 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1.0 В; I_S < 0.2 мкА; C_D < 5.0 пФ; I_{TERR} < 5 нС$	SOT23, SOD23	K1-K2; A1, A2
46	PDTA114TEF	PHIL	Dnprn	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{FE1} > 200; R_{11}, R_{10} < 10 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
46p	BAS4006	PHIL	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 380 мВ; C_D < 5 пФ$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
46s	BAS4006	SIEM	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1.0 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5.0 пФ$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
46s	BAS40-06	INF	shd-2	$V_R < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 40 мА) < 1 В; I_S < 1.0 мкА; C_D < 5 пФ$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типонаимал	СИ	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
46s	BAS406W	SIEM	shd-2	$V_B < 40 \text{ В}; I_C < 120 \text{ мА}; V_{CE}(I_C=15 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{ES} < 1.0 \text{ мА}; C_{CB} < 5.0 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	K1+K2-A1,A2
46s	BAS40-06W	INF	shd-2	$V_B < 40 \text{ В}; I_C < 120 \text{ мА}; V_{CE}(I_C=40 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_{ES} < 1.0 \text{ мА}; C_{CB} < 5 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	K1+K2-A1,A2
47	PDTCT114YK	PHIL	Dnnp	$V_{CE(sat)}: 50 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 200 \text{ мВт}; h_{FE1}: 100; 10 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
47p	PMBFJ113	PHIL	nFET	$V_{DS}: 40 \text{ В}; I_{DSS} > 2 \text{ мА}; P_D: 300 \text{ мВт}; P_{D(oss)} < 100 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	D-S-G
47f	PMBFJ113	PHIL	nFET	$V_{DS}: 40 \text{ В}; I_{DSS} > 2 \text{ мА}; P_D: 300 \text{ мВт}; P_{D(oss)} < 100 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	D-S-G
47V	PZM47NB	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=2 \text{ мА})=44.0...50.0 \text{ В}; Z_{TZ}(I_{ZT}=2 \text{ мА}) < 90 \text{ Ом}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
47W	PMBFJ113	PHIL	nFET	$V_{DS}: 40 \text{ В}; I_{DSS} > 2 \text{ мА}; P_D: 300 \text{ мВт}; P_{D(oss)} < 100 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	D-S-G
47X	O2CZ47	TOSH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=2 \text{ мА})=44.00...49.00 \text{ В}; I_{ZT}(I_{ZT}=36 \text{ В}) < 0.5 \text{ мкА}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
489	FMMT489	ZETEX	npn	$V_{CE(sat)}: 50 \text{ В}; I_C: 1000 \text{ мА}; P_D: 500 \text{ мВт}; h_{FE1}: 100...300; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
48p	PMBFJ308	PHIL	nFET	$V_{DS}: 25 \text{ В}; I_{DSS} = 12...60 \text{ мА}; P_D: 250 \text{ мВт}; g_{FS} > 10 \text{ мСм}$	SOT23,SOD23	S-D-G
48t	PMBFJ308	PHIL	nFET	$V_{DS}: 25 \text{ В}; I_{DSS} = 12...60 \text{ мА}; P_D: 250 \text{ мВт}; g_{FS} > 10 \text{ мСм}$	SOT23,SOD23	S-D-G
48W	PMBFJ308	PHIL	nFET	$V_{DS}: 25 \text{ В}; I_{DSS} = 12...60 \text{ мА}; P_D: 250 \text{ мВт}; g_{FS} > 10 \text{ мСм}$	SOT23,SOD23	S-D-G
491	FMMT491	ZETEX	npn	$V_{CE(sat)}: 80 \text{ В}; I_C: 1000 \text{ мА}; P_D: 500 \text{ мВт}; h_{FE1}: 100...300; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
493	FMMT493	ZETEX	npn	$V_{CE(sat)}: 120 \text{ В}; I_C: 1000 \text{ мА}; P_D: 500 \text{ мВт}; h_{FE1}: 100...300; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
494	FMMT494	ZETEX	npn	$V_{CE(sat)}: 140 \text{ В}; I_C: 1000 \text{ мА}; P_D: 500 \text{ мВт}; h_{FE1}: 100...300; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
495	FMMT495	ZETEX	npn	$V_{CE(sat)}: 170 \text{ В}; I_C: 1000 \text{ мА}; P_D: 500 \text{ мВт}; h_{FE1}: 100...300; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
497	FMMT497	ZETEX	npn	$V_{CE(sat)}: 300 \text{ В}; I_C: 500 \text{ мА}; P_D: 500 \text{ мВт}; h_{FE1}: 80...300; f_T > 75 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
49p	PMBFJ309	PHIL	nFET	$V_{DS}: 25 \text{ В}; I_{DSS} = 12...30 \text{ мА}; P_D: 250 \text{ мВт}; g_{FS} > 10 \text{ мСм}$	SOT23,SOD23	S-D-G
49t	PMBFJ309	PHIL	nFET	$V_{DS}: 25 \text{ В}; I_{DSS} = 12...30 \text{ мА}; P_D: 250 \text{ мВт}; g_{FS} > 10 \text{ мСм}$	SOT23,SOD23	S-D-G
49W	PMBFJ309	PHIL	nFET	$V_{DS}: 25 \text{ В}; I_{DSS} = 12...30 \text{ мА}; P_D: 250 \text{ мВт}; g_{FS} > 10 \text{ мСм}$	SOT23,SOD23	S-D-G
4A	BC859A	CDIL	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 310 \text{ мВт}; h_{FE1}: 110...220; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4A	BC859AW	PHIL	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 200 \text{ мВт}; h_{FE1}: 125...250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SC70	B-E-C
4A	FMMV109	ZETEX	bd	$V_B < 30 \text{ В}; C_{CB} < 26...32 \text{ нФ}; C_{3B}/C_{26B} < 5...6.5; Q > 250$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
4A	MMBV109	ZETEX	var	$V_B > 30 \text{ В}; I_C: 200 \text{ мА}; C_{3B} < 26...32 \text{ нФ}; C_{3B}/C_{26B} < 5.0...6.5$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
4A3	PZM4.3NB2A	PHIL	dz-2	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ мА})=4.15...4.34 \text{ В}; Z_{TZ}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 90 \text{ Ом}$	SOT346,SC59	K1+K2-A1,A2
4A7	PZM4.7NB2A	PHIL	dz-2	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ мА})=4.55...4.75 \text{ В}; Z_{TZ}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$	SOT346,SC59	K1+K2-A1,A2
4Ap	BC859A	PHIL	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 250 \text{ мВт}; h_{FE1}: 125...250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4AR	BC859AR	PHIL	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 200 \text{ мВт}; h_{FE1}: 250; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	E-B-C
4As	BC859A	SIEM	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 330 \text{ мВт}; h_{FE1}: 125...250; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4Aa	BC859AW	INF	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 250 \text{ мВт}; h_{FE1}: 125...250; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4At	BC859A	PHIL	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 250 \text{ мВт}; h_{FE1}: 125...250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4B	BC859B	CDIL	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 330 \text{ мВт}; h_{FE1}: 220...475; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4B	BC859B	TOSH	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 150 \text{ мВт}; h_{FE1}: 220...475; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4B	BC859B	ZETEX	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 330 \text{ мВт}; h_{FE1}: 220...475; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4B	BC859B	ITT	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 330 \text{ мВт}; h_{FE1}: 220...475; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4B-	BC859BW	PHIL	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 200 \text{ мВт}; h_{FE1}: 220...475; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4Bp	BC859B	PHIL	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 250 \text{ мВт}; h_{FE1}: 220...475; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4BR	BC859BR	PHIL	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 200 \text{ мВт}; h_{FE1}: 475; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	E-B-C
4Bs	BC859B	INF	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 330 \text{ мВт}; h_{FE1}: 220...475; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4Bs	BC859BW	SIEM	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 250 \text{ мВт}; h_{FE1}: 220...475; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4Bt	BC859B	PHIL	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 250 \text{ мВт}; h_{FE1}: 220...475; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4Bt	BC859BW	PHIL	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 200 \text{ мВт}; h_{FE1}: 220...475; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4C	BC859C	ITT	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 250 \text{ мВт}; h_{FE1}: 220...475; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4C	BC859C	CDIL	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 330 \text{ мВт}; h_{FE1}: 420...800; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4C	BC859C	TOSH	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 150 \text{ мВт}; h_{FE1}: 420...800; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4C	BC859C	ITT	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 330 \text{ мВт}; h_{FE1}: 420...800; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4C	FMMV3102	ZETEX	bd	$V_B < 30 \text{ В}; C_{CB} < 20...25 \text{ нФ}; C_{3B}/C_{26B} > 4.5; Q > 300$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
4C	MMVB3102	MOT	var	$C_T < 6...35 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
4C-	BC859CW	PHIL	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 200 \text{ мВт}; h_{FE1}: 420...800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4Cp	BC859C	PHIL	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 250 \text{ мВт}; h_{FE1}: 420...800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4CR	BC859CR	PHIL	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 200 \text{ мВт}; h_{FE1}: 800; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	E-B-C
4Cs	BC859C	INF	npn	$V_{CE(sat)}: 30 \text{ В}; I_C: 100 \text{ мА}; P_D: 330 \text{ мВт}; h_{FE1}: 420...800; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3
VMD3



SOT416
SOT523

SOT323
SOT346

SOT23-3
SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
4Cs	BC859CW	INF	rnp	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 420..800; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4Cl	BC859C	PHL	rnp	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 420..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4Cl	BC859CW	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 200 \text{ мВт}; h_{21} > 420..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4D	BC859	CDIL	rnp	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 125..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4D	HD3A	ZETEX	fid	$V_{BE} < 75 \text{ В}; I_E < 100 \text{ мА}; V_{CE}(I_E = 10 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_B < 1.0 \text{ мкА}; C_{CE} < 4.0 \text{ нФ}; I_{RR} < 6 \text{ мс}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
4D	MMBV3401LT1	ON	pin	$V_{BR} > 35 \text{ В}; I_B < 0.1 \text{ мкА}; C_T < 1 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
4D-	BC859W	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 200 \text{ мВт}; h_{21} > 125..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4Dp	BC859	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 125..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4Di	BC859W	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 200 \text{ мВт}; h_{21} > 125..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4E	BC860A	CDIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 125..250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4E	BC860AW	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 200 \text{ мВт}; h_{21} > 125..250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4E	FMMTA92	ZETEX	rnp	$V_{CEB} > 300 \text{ В}; I_C > 200 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; h_{21} > 25; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4E	BC860A	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 125..250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4ER	BC860AR	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 45 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 200 \text{ мВт}; h_{21} > 250; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4Et	BC860A	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 125..250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4EZ	FMMV105G	ZETEX	bd	$V_{BE} < 30 \text{ В}; C_{CEB} = 1.8..2.8 \text{ нФ}; C3 \text{ В}/C_{CEB} = 4..6; Q > 350$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
4F	BC860B	CDIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; h_{21} > 220..475; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4F	BC860B	ZETEX	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; h_{21} > 220..475; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4F-	BC860BW	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 200 \text{ мВт}; h_{21} > 220..475; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4Fp	BC860B	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 220..475; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4FR	BC860BR	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 45 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 200 \text{ мВт}; h_{21} > 475; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	E-B-C
4Fs	BC860B	INF	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; h_{21} > 220..475; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4Ff	BC860BW	INF	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 220..475; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4Ft	BC860B	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 220..475; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4Ft	BC860BW	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 200 \text{ мВт}; h_{21} > 220..475; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4G	BC860C	CDIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 420..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4G	FMMT2484	ZETEX	rnp	$V_{CEB} > 60 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; h_{21} > 100..500$	SOT23,SOD23	B-E-C
4G-	BC860CW	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 200 \text{ мВт}; h_{21} > 420..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4Gr	BC860C	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 420..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4GR	BC860CR	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 45 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 200 \text{ мВт}; h_{21} > 800; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	E-B-C
4Gs	BC850CW	INF	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 420..800; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4Gs	BC860C	INF	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; h_{21} > 420..800; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4Gs	BC860CW	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 420..800; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4Gt	BC860C	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 420..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4Gt	BC860CW	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 200 \text{ мВт}; h_{21} > 420..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4GZ	BC860C	ZETEX	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; h_{21} > 420..800; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4H	BC860	CDIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 125..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4H-	MMBV2103LT1	MOT	var	$V_{BE} > 30 \text{ В}; I_E > 200 \text{ мА}; C_{4E} = 9..11 \text{ нФ}; C_{2E} \text{ в } C_{30B} = 2.5..3.2$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
4H-	BC860W	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 200 \text{ мВт}; h_{21} > 125..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4Hp	BC860	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 125..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4Ht	BC860	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 250 \text{ мВт}; h_{21} > 125..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4Ht	BC860W	PHIL	rnp	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D > 200 \text{ мВт}; h_{21} > 125..800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
4J	FMMT38A	ZETEX	rnp	$V_{CEB} > 80 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; h_{21} > 500$	SOT23,SOD23	B-E-C
4J	MMBV2109LT1	MOT	var	$V_{BE} > 30 \text{ В}; I_E > 200 \text{ мА}; C_{4E} = 29.7..36.3 \text{ нФ}; C_{2E} \text{ в } C_{30B} = 2.5..3.2$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
4M	MMBD101	MOT	shd	$V_{BE} < 4 \text{ В}; V_{BE}(I_E = 10 \text{ мА}) < 0.6 \text{ В}; I_B < 0.25 \text{ мкА}; C_T < 1 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
4Ms	BAT240A	INF	shd-2	$V_{BE} < 240 \text{ В}; I_C < 400 \text{ мА}; V_{BE}(I_E = 50 \text{ мА}) < 470 \text{ мВ}; C_T = 11.5 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1A2-K2-A1
4P	FMMT2907R	ZETEX	rnp	$V_{CEB} > 60 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; h_{21} > 100..300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4R	MMBV3700LT1	ON	pin	$V_{BR} > 200 \text{ В}; I_B < 0.1 \text{ мкА}; C_T < 1 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
4T	MMBD301LT1	ON	shd	$V_{BE} > 30 \text{ В}; V_{BE}(I_E = 10 \text{ мА}) < 0.6 \text{ В}; C_T < 1.5 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
4U	MMBV2105LT1	MOT	var	$V_{BE} > 30 \text{ В}; I_E > 200 \text{ мА}; C_{4E} = 13.5..16.5 \text{ нФ}; C_{2E} \text{ в } C_{30B} = 2.5..3.2$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
4V	BCW65AR	ZETEX	rnp	$V_{CEB} > 60 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; h_{21} > 100..250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
4V	MMBV2106LT1	MOT	var	$V_{BE} > 30 \text{ В}; I_E > 200 \text{ мА}; C_{2E} \text{ в } C_{30B} = 2.5..3.2$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
4V3	PZM4.3NB	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})=4.01\dots4.48\text{ В}; Z_{TE}(I_{CE}=5\text{ mA}) < 90\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A•n.c.•K
4V7	PZM4.7NB	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})=4.42\dots4.90\text{ В}; Z_{TE}(I_{CE}=5\text{ mA}) < 80\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A•n.c.•K
4W	BCW67AR	ZETEX	pnnp	$V_{CE0}=45\text{ В}; I_C=800\text{ mA}; P_D=330\text{ мВт}; h_{FE1}=100\dots250; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
4W	MMBV2107LT1	MOT	var	$V_B > 30\text{ В}; I_C=200\text{ mA}; C_{4B}=19.8\dots24.2\text{ нФ}; C_{2B}/C_{30B}=2.5\dots3.2$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4X	MMBV2108LT1	MOT	var	$V_B > 30\text{ В}; I_C=200\text{ mA}; C_{4B}=24.3\dots29.7\text{ нФ}; C_{2B}/C_{30B}=2.5\dots3.2$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4Y	MMBV2102LT1	MOT	var	$V_B > 30\text{ В}; C_{1T}=8.2\text{ нФ}; C_{2B}/C_{30B}=2.5\dots3.2$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
4Z	MMBV2104LT1	MOT	var	$V_B > 30\text{ В}; I_C=200\text{ mA}; C_{2B}/C_{30B}=2.5\dots3.2$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
5.1X	O2C25.1	TOSH	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})=4.80\dots5.40\text{ В}; I_C(V_{CE}=1.5\text{ В}) < 1\text{ мкА}; Z_{TE}(I_{CE}=0.5\text{ mA}) < 1000\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A•n.c.•K
5.6X	O2C25.6	TOSH	dz	$V_{CE}(I_{CE}=5\text{ mA})=5.30\dots6.00\text{ В}; I_C(V_{CE}=2.5\text{ В}) < 1\text{ мкА}; Z_{TE}(I_{CE}=0.5\text{ mA}) < 900\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A•n.c.•K
50P	PDTA143EEF	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=250\text{ мВт}; h_{FE1} > 30; 4.7\text{ кОм}/4.7\text{ кОм}$	SOT490,SC89	B•E•C
50P	PMBFJ310	PHIL	nFET	$V_{GS}=25\text{ В}; I_{DSS}=24\dots60\text{ mA}; P_D=250\text{ мВт}; g_p > 10\text{ мСм}$	SOT23,SOD23	S•D•G
50P	PMBFJ310	PHIL	nFET	$V_{GS}=25\text{ В}; I_{DSS}=24\dots60\text{ mA}; P_D=250\text{ мВт}; g_p > 10\text{ мСм}$	SOT23,SOD23	S•D•G
50P	PMBFJ310	PHIL	nFET	$V_{GS}=25\text{ В}; I_{DSS}=24\dots60\text{ mA}; P_D=250\text{ мВт}; g_p > 10\text{ мСм}$	SOT23,SOD23	S•D•G
51	PDTC143EEF	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=250\text{ мВт}; h_{FE1} > 30; 4.7\text{ кОм}/4.7\text{ кОм}$	SOT490,SC89	B•E•C
517	FMMT6517	ZETEX	pnnp	$V_{CE0}=350\text{ В}; I_C=500\text{ mA}; P_D=330\text{ мВт}; h_{FE1} > 300; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
51V	PZM51NB	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=2\text{ mA})=48.0\dots54.0\text{ В}; Z_{TE}(I_{CE}=2\text{ mA}) < 110\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A•n.c.~K
52	DTA123YE	ROHM	Dnpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=150\text{ мВт}; h_{FE1} > 33; f_T > 250\text{ МГц}; R_1/R_2=2.2/10\text{ кОм}$	SOT416,SC75A	B•E•C
52	DTA123YKA	ROHM	Dnpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; h_{FE1} > 33; f_T > 250\text{ МГц}; R_1/R_2=2.2/10\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B•E•C
52	DTA123YUA	ROHM	Dnpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=500\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; h_{FE1} > 56; f_T > 250\text{ МГц}; R_1/R_2=2.2/10\text{ кОм}$	SOT323,SC70	B•E•C
52	PDTA143ZEF	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=250\text{ мВт}; h_{FE1} > 100; 4.7\text{ кОм}/4.7\text{ кОм}$	SOT490,SC89	B•E•C
520	FMMT6520	ZETEX	pnnp	$V_{CE0}=350\text{ В}; I_C=500\text{ mA}; P_D=330\text{ мВт}; h_{FE1} > 300; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
53	BAT17	SIEM	shd	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 30\text{ mA}; V_{FE}(I_C=10\text{ mA}) < 0.6\text{ В}; I_B < 0.25\text{ мкА}; C_D < 1\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K
53	BAT17W	SIEM	shd	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 130\text{ mA}; V_{FE}(I_C=10\text{ mA}) < 0.6\text{ В}; I_B < 0.25\text{ мкА}; C_D < 0.75\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A•n.c.~K
53	PDTC143ZEF	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=250\text{ мВт}; h_{FE1} > 100; 4.7\text{ кОм}/4.7\text{ кОм}$	SOT490,SC89	B•E•C
53s	BAT17	INF	shd-2	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 130\text{ mA}; V_{FE}(I_C=1\text{ mA}) < 450\text{ мВ}; C_D < 1\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A•n.c.~C
53s	BAT17W	INF	shd	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 130\text{ mA}; V_{FE}(I_C=10\text{ mA}) < 0.6\text{ В}; I_B < 0.25\text{ мкА}; C_D < 0.75\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A•n.c.~K
54	BAT1704	SIEM	shd-2	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 130\text{ mA}; V_{FE}(I_C=10\text{ mA}) < 0.6\text{ В}; I_B < 0.25\text{ мкА}; C_D < 1\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
54	BAT1704W	SIEM	shd-2	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 130\text{ mA}; V_{FE}(I_C=10\text{ mA}) < 0.6\text{ В}; I_B < 0.25\text{ мкА}; C_D < 0.75\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
54	DTA114YE	ROHM	Dnpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=150\text{ мВт}; h_{FE1} > 68; f_T > 250\text{ МГц}; R_1/R_2=10/47\text{ кОм}$	SOT416,SC75A	B•E•C
54	DTA114YKA	ROHM	Dnpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; h_{FE1} > 68; f_T > 250\text{ МГц}; R_1/R_2=10/4.7\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B•E•C
54	DTA114YUA	ROHM	Dnpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; h_{FE1} > 68; f_T > 250\text{ МГц}; R_1/R_2=10/47\text{ кОм}$	SOT323,SC70	B•E•C
54	PDTA141YK	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; h_{FE1} > 100; 10\text{ кОм}/4.7\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B•E•C
54	PDTC143XEF	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=250\text{ мВт}; h_{FE1} > 50; 4.7\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT490,SC89	B•E•C
549	FMMT549	ZETEX	pnnp	$V_{CE0}=35\text{ В}; I_C=1000\text{ mA}; P_D=500\text{ мВт}; h_{FE1} > 100\dots300; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
54s	BAT17-04	INF	shd-2	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 130\text{ mA}; V_{FE}(I_C=1\text{ mA}) < 450\text{ мВ}; C_D < 1\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
54s	BAT17-04W	INF	shd-2	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 130\text{ mA}; V_{FE}(I_C=10\text{ mA}) < 0.6\text{ В}; I_B < 0.25\text{ мкА}; C_D < 0.75\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
55	BAT1705	SIEM	shd-2	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 130\text{ mA}; V_{FE}(I_C=10\text{ mA}) < 0.6\text{ В}; I_B < 0.25\text{ мкА}; C_D < 1\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
55	BAT1705W	SIEM	shd-2	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 130\text{ mA}; V_{FE}(I_C=10\text{ mA}) < 0.6\text{ В}; I_B < 0.25\text{ мкА}; C_D < 0.75\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
551	FMMT551	ZETEX	pnnp	$V_{CE0}=80\text{ В}; I_C=1000\text{ mA}; P_D=500\text{ мВт}; h_{FE1} > 50\dots150; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
555	FMMT555	ZETEX	pnnp	$V_{CE0}=160\text{ В}; I_C=1000\text{ mA}; P_D=500\text{ мВт}; h_{FE1} > 50\dots300; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
555	FMMT558	ZETEX	pnnp	$V_{CE0}=400\text{ В}; I_C=150\text{ mA}; P_D=500\text{ мВт}; h_{FE1} > 100\dots300; f_T > 50\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
55s	BAT17-05	INF	shd-2	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 130\text{ mA}; V_{FE}(I_C=1\text{ mA}) < 450\text{ мВ}; C_D < 1\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,K2
55s	BAT17-05W	INF	shd-2	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 130\text{ mA}; V_{FE}(I_C=1\text{ mA}) < 450\text{ мВ}; C_D < 1\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
56	BAT1706	SIEM	shd-2	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 130\text{ mA}; V_{FE}(I_C=10\text{ mA}) < 0.6\text{ В}; I_B < 0.25\text{ мкА}; C_D < 1\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
56	BAT1706W	SIEM	shd-2	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 130\text{ mA}; V_{FE}(I_C=10\text{ mA}) < 0.6\text{ В}; I_B < 0.25\text{ мкА}; C_D < 0.75\text{ нФ}$	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
56s	BAT17-06	INF	shd-2	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 130\text{ mA}; V_{FE}(I_C=1\text{ mA}) < 450\text{ мВ}; C_D < 1\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
56s	BAT17-06W	INF	shd-2	$V_B < 4\text{ В}; I_C < 130\text{ mA}; V_{FE}(I_C=10\text{ mA}) < 0.6\text{ В}; I_B < 0.25\text{ мкА}; C_D < 0.75\text{ нФ}$	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
56V	PZM56NB	PHIL	dz	$V_{CE}(I_{CE}=2\text{ mA})=52.0\dots60.0\text{ В}; Z_{TE}(I_{CE}=2\text{ mA}) < 120\text{ Ом}$	SOT346,SC59	A•n.c.~K
576	FMMT576	ZETEX	pnnp	$V_{CE0}=200\text{ В}; I_C=1000\text{ mA}; P_D=500\text{ мВт}; h_{FE1} > 50\dots300; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
589	FMMT589	ZETEX	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 1000 \text{ мА}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 100...300; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
59	DTA114YE	MOT	Dpnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 68; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 10/47 \text{ К/Ом}$	SOT416.SC75A	B•E•C
591	FMMT591	ZETEX	rnp	$V_{CB0} = 80 \text{ В}; I_C = 1000 \text{ мА}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 100...300; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
593	FMMT593	ZETEX	rnp	$V_{CB0} = 120 \text{ В}; I_C = 1000 \text{ мА}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 100...300; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
596	FMMT596	ZETEX	rnp	$V_{CB0} = 220 \text{ В}; I_C = 300 \text{ мА}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 85...300; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
597	FMMT597	ZETEX	rnp	$V_{CB0} = 300 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 100...300; f_T > 75 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
59A	FMMT549A	ZETEX	rnp	$V_{CB0} = 35 \text{ В}; I_C = 1000 \text{ мА}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 150...500; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5A	BC807-16	CDIL	rnp	$V_{CB0} = 45 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 100...250; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5A	BC807-16LT1	MOT	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 100...250; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5A	BC807-16W	PHIL	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 100...250; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT323.SC70	B•E•C
5A	BSS123	MOT	nMOS	$V_{GS} = 100 \text{ В}; I_D = 170 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; g_{fs} = 90 \text{ мСм}; R_{DS(on)} = 14 \text{ Ом}$	SOT23.SOD23	G•S•D
5A	FMMD6050	ZETEX	fid	$V_{GS} < 70 \text{ В}; I_D < 200 \text{ мА}; V_{FI}(I_D = 100 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; I_{RR} < 0.1 \text{ мА}; C_{GS} < 2.5 \text{ нФ}; t_{RR} < 5 \text{ нс}$	SOT23.SOD23	A•n.c.•K
5A	MMBD6050LT1	MOT	di	$V_{GS} > 70 \text{ В}; I_D < 200 \text{ мА}; V_{FI}(I_D = 100 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; C_{GS} < 2.5 \text{ нФ}; t_{RR} < 4 \text{ нс}$	SOT23.SOD23	A•n.c.•K
5A1	PZM5.1NB2A	PHIL	dz-2	$V_{Z1}(I_Z = 5 \text{ мА}) = 4.98...5.20 \text{ В}; Z_{T1}(I_Z = 5 \text{ мА}) < 60 \text{ Ом}$	SOT346.SC59	K1•K2•A1•A2
5A6	MMBZ5V6AL	ON	dz-2	$V_{Z1}(I_Z = 1 \text{ мА}) = 5.32...5.88 \text{ В}; V_{FI}(I_F = 10 \text{ мА}) < 0.9 \text{ В}$	SOT23.SOD23	K1•K2•A1•A2
5A6	PZM5.6NB2A	PHIL	dz-2	$V_{Z1}(I_Z = 5 \text{ мА}) = 5.49...5.73 \text{ В}; Z_{T1}(I_Z = 5 \text{ мА}) < 40 \text{ Ом}$	SOT346.SC59	K1•K2•A1•A2
5Ap	BC807-16	PHIL	rnp	$V_{CB0} = 45 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 100...250; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5AR	BC807-16R	PHIL	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	E•B•C
5As	BC807-16	SIEM	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 100...250; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5As	BC807-16W	SIEM	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 100...250; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT323.SC70	B•E•C
5AZ	BC807-16	ZETEX	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 100...250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5B	BC80725	CDIL	rnp	$V_{CB0} = 45 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 160...400; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5B	BC807-25	STM	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 160...400; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5B	BC80725LT1	MOT	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 160...400; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5B	BC80725W	PHIL	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 160...400; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT323.SC70	B•E•C
5B	FMMD6100	ZETEX	fid-2	$V_{GS} < 70 \text{ В}; I_D < 200 \text{ мА}; V_{FI}(I_D = 100 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; I_{RR} < 0.1 \text{ мА}; C_{GS} < 2.5 \text{ нФ}; t_{RR} < 5 \text{ нс}$	SOT23.SOD23	A1•A2•K1•K2
5B	KST4123	SAMS	nnpn	$V_{CB0} = 40 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 50...150; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5B	MMBT4123	SAMS	nnpn	$V_{CB0} = 40 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 50...150$	SOT23.SOD23	B•E•C
5B	MMBT4123	MOT	nnpn	$V_{CB0} = 40 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 50...150$	SOT23.SOD23	B•E•C
5BM	MMBD6100LT1	MOT	di-2	$V_{GS} > 70 \text{ В}; I_D < 200 \text{ мА}; V_{FI}(I_D = 100 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; C_{GS} < 2.5 \text{ нФ}; t_{RR} < 4 \text{ нс}$	SOT23.SOD23	A1•A2•K1•K2
5Bp	BC80725	PHIL	rnp	$V_{CB0} = 45 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 160...400; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5Bs	BC80725	SIEM	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 160...400; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5Bs	BC80725W	SIEM	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 160...400; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT323.SC70	B•E•C
5Bt	BC80725	PHIL	rnp	$V_{CB0} = 45 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 160...400; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5BZ	BC80725	ZETEX	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 160...400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5C	BAT54CLT1	ON	shd-2	$V_{GS} < 30 \text{ В}; I_D < 200 \text{ мА}; V_{FI}(I_D = 30 \text{ мА}) < 500 \text{ мВ}; t_{RR} < 5 \text{ нс}$	SOT23.SOD23	A1•A2•K1•K2
5C	BC807-40	CDIL	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 250...630; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5C	BC807-40	STM	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 250...600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5C	BC80740LT1	MOT	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 250...600; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5C	BC807-40W	PHIL	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 250...600; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT323.SC70	B•E•C
5C	FMMD7000	ZETEX	fid-2	$V_{GS} < 70 \text{ В}; I_D < 200 \text{ мА}; V_{FI}(I_D = 100 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; I_{RR} < 0.3 \text{ мА}; C_{GS} < 2.5 \text{ нФ}; t_{RR} < 15 \text{ нс}$	SOT23.SOD23	A1•K2•K1•A2
5CR	BC807-40	PHIL	rnp	$V_{CB0} = 45 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 250...600; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5Cp	BC807-40R	PHIL	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 310 \text{ мВт}; h_{21} = 600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5Cs	BC807-40	SIEM	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 250...630; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5Cs	BC807-40W	INF	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 250...630; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT323.SC70	B•E•C
5CZ	BC807-40	ZETEX	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 250...600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5D	BC807	CDIL	rnp	$V_{CB0} = 45 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 100...600; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23.SOD23	B•E•C
5D	BC807W	PHIL	rnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 100...600; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT323.SC70	B•E•C
5D	DAN212N3	CYS	di	$V_{GS} < 70 \text{ В}; I_D < 200 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; V_{FI}(I_D = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; t_{RR} < 4 \text{ нс}$	SOT23.SOD23	A•n.c.•K



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
5D	FMMD914	ZETEX	fid	$V_B < 75 \text{ В}; I_C < 225 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 10 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{ES} < 0.025 \text{ мА}; C_{\Sigma} < 4.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 8 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A•n.c. •K
5D	HD2A	ZETEX	fid-2	$V_B < 35 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 10 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{ES} < 1.0 \text{ мА}; C_{\Sigma} < 4.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 6 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1 •A2 •K1,K2
5D	MMBD914LT1	MOT	di	$V_B > 100 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 10 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_{\Sigma} < 4 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 4 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A•n.c. •K
5D	TMPD4148	ALLEG	d	$I_C < 600 \text{ мА}; V_{BR} > 100 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 10 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{ES} < 25 \text{ нА}; t_{\text{рег}} < 4.0 \text{ нс}; C_{\Sigma} < 4.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A•n.c. •K
5D	TMPD914	ALLEG	d	$I_C < 600 \text{ мА}; V_{BR} > 100 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 10 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{ES} < 25 \text{ нА}; t_{\text{рег}} < 4.0 \text{ нс}; C_{\Sigma} < 6.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A•n.c. •K
5Dp	BC807	PHIL	npn	$V_{CEB} < 45 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...600; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5DZ	BC807	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 50 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5E	BC808-16	CDIL	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5E	BC808-16W	PHIL	npn	$V_{CEB} < 25 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...250; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23,SC70	B •E •C
5E	FMMTA43R	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 200 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50...200; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5EP	BC808-16	PHIL	npn	$V_{CEB} < 25 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...250; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5ER	BC808-16R	PHIL	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 310 \text{ мВт}; h_{FE1} > 250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	E •B •C
5Es	BC808-16	SIEM	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...250; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5Es	BC808-16W	INF	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...250; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SC70	B •E •C
5Et	BC808-16	PHIL	npn	$V_{CEB} < 25 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...250; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5EZ	BC808-16	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5F	BC808-25	CDIL	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 160...400; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5F	BC808-25W	PHIL	npn	$V_{CEB} < 25 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 160...400; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23,SC70	B •E •C
5FP	BC808-25	PHIL	npn	$V_{CEB} < 25 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 160...400; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5FR	BC808-25R	PHIL	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 310 \text{ мВт}; h_{FE1} > 400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	E •B •C
5Fs	BC808-25	SIEM	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 160...400; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5Fs	BC808-25W	INF	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 160...400; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SC70	B •E •C
5FZ	BC80825	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 160...400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5G	BC808-40	CDIL	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 250...630; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5G	BC808-40W	PHIL	npn	$V_{CEB} < 25 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 250...600; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23,SC70	B •E •C
5Gp	BC808-40	PHIL	npn	$V_{CEB} < 25 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 250...600; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5GR	BC808-40R	PHIL	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 310 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	E •B •C
5Gs	BC808-40	SIEM	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 250...630; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5Gs	BC808-40W	INF	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 250...630; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SC70	B •E •C
5Gt	BC808-40	PHIL	npn	$V_{CEB} < 25 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 250...600; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5GZ	BC808-40	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 250...600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5H	BC808	CDIL	npn	$V_{CEB} < 25 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...600; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5H	BC808W	PHIL	npn	$V_{CEB} < 25 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...600; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23,SC70	B •E •C
5H	MMBD4148	VISH	di	$V_B < 75 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 10 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{ES} < 5.0 \text{ мА}; C_{\Sigma} < 4 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 6 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A•n.c. •K
5H	MMBD4148	NS	di	$V_B < 75 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 10 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{ES} < 5.0 \text{ мА}; C_{\Sigma} < 4 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 6 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A•n.c. •K
5H	MMBD701LT1	MOT	shd	$V_B > 70 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 10 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_{\Sigma} < 1 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A•n.c. •K
5Hq	BC808	PHIL	npn	$V_{CEB} < 25 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...600; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5HZ	BC808	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5J	FMMT38B	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 80 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 2000$	SOT23,SOD23	B •E •C
5K	MMBV609LT1	ON	var	$V_B > 20 \text{ В}; I_F > 20 \text{ мА}; C_{2B} < 4.5...6.1 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{8B} < 1.8...2.6$	SOT23,SOD23	A•n.c. •K
5L	MMBV609LT1	ON	var-2	$V_B > 20 \text{ В}; I_F > 100 \text{ мА}; C_{2B} < 26...32 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{8B} < 1.8...2.4$	SOT23,SOD23	A1 •A2 •K1,K2
5N	MMBD452LT1	MOT	shd-2	$V_B > 30 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 10 \text{ мА}) < 0.45 \text{ В}; C_{\Sigma} < 1.5 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1 •K2 •K1,K2
5P	FMMT2907AR	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5T	BCW66GR	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 75 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 160...400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5T	BCW66GR	SIEM	npn	$V_{CEB} < 75 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 160...400; f_T > 170 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	C •B •E
5T	BCW68GR	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 160...400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5V	BCW65BR	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 160...400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B •E •C
5V1	PZM5.1NB	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_T = 5 \text{ мА}) = 4.84...5.37 \text{ В}; Z_{T1}(I_T = 5 \text{ мА}) < 60 \text{ Ом}$	SOT346,SC59	A•n.c. •K
5V6	PZM5.6NB	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_T = 5 \text{ мА}) = 5.31...5.92 \text{ В}; Z_{T1}(I_T = 5 \text{ мА}) < 40 \text{ Ом}$	SOT346,SC59	A•n.c. •K

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
5W	BCW67BR	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 45 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} < 160; .400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E•C
6.2X	02C26.2	TOSH	dz	$V_{ZT}(I_Z=5 \text{ мА}) < 5.80 \dots 6.60 \text{ В}; I_V(I_V=3.0 \text{ В}) < 1 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z=0.5 \text{ мА}) < 500 \text{ Ом}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
6.8	DF346.8FU	TOSH	pz-2	$V_{ZT}(I_Z=5 \text{ мА}) < 6.4 \dots 7.2 \text{ В}; I_V(I_V=5.0 \text{ В}) < 0.5 \text{ мкА}$	SOT323,SC70	K1-K2-A1,A2
6.8X	02C26.8	TOSH	dz	$V_{ZT}(I_Z=5 \text{ мА}) < 6.40 \dots 7.20 \text{ В}; I_V(I_V=5.0 \text{ В}) < 0.5 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z=0.5 \text{ мА}) < 150 \text{ Ом}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
6-14	FMMT614	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 120 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 500 \text{ мВт}; h_{21} > 15000$	SOT23,SOD23	B-E•C
617	FMMT617	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 15 \text{ В}; I_C < 3000 \text{ мА}; P_D < 625 \text{ мВт}$	SOT23,SOD23	B-E•C
618	FMMT618	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 20 \text{ В}; I_C < 2500 \text{ мА}; P_D < 625 \text{ мВт}; h_{21} > 300 \dots 450; f_T > 140 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E•C
619	FMMT619	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 50 \text{ В}; I_C < 2000 \text{ мА}; P_D < 625 \text{ мВт}; h_{21} > 300 \dots 450; f_T > 160 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E•C
61A	MMBF4117	FAIR	nFET	$V_{DG} < 40 \text{ В}; I_{GF} < 50 \text{ мА}; P_D < 225 \text{ мВт}; g_{FS} < 3 \text{ мС}$	SOT23,SOD23	D-S•G
61C	MMBF4118	FAIR	nFET	$V_{DG} < 40 \text{ В}; I_{GF} < 50 \text{ мА}; P_D < 225 \text{ мВт}; g_{FS} < 5 \text{ мС}$	SOT23,SOD23	D-S•G
61E	MMBF4119	FAIR	nFET	$V_{DG} < 40 \text{ В}; I_{GF} < 50 \text{ мА}; P_D < 225 \text{ мВт}; g_{FS} < 10 \text{ мС}$	SOT23,SOD23	D-S•G
61J	MMBF4091	FAIR	nFET	$V_{DG} < 40 \text{ В}; I_{GF} < 50 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 30 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	S-D•G
61K	MMBF4092	FAIR	nFET	$V_{DG} < 40 \text{ В}; I_{GF} < 50 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 50 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	S-D•G
61L	MMBF4093	FAIR	nFET	$V_{DG} < 40 \text{ В}; I_{GF} < 50 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 80 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	S-D•G
61S	MMBF5458	FAIR	nFET	$V_{DG} < 25 \text{ В}; I_{GF} < 10 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{OSS} < 9 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	S-D•G
61S	MMBFJ270	FAIR	pFET	$V_{DG} < 30 \text{ В}; I_{GF} < 50 \text{ мА}; P_D < 225 \text{ мВт}; I_{OSS} < 15 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	D-S•G
61T	MMBF5459	NS	nFET	$V_{DG} < 25 \text{ В}; I_{GF} < 10 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{OSS} < 16 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	S-D•G
61U	MMBF5461	FAIR	pFET	$V_{DG} < 40 \text{ В}; I_{GF} < 10 \text{ мА}; P_D < 300 \text{ мВт}; I_{OSS} < 9 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	D-S•G
61V	MMBF5462	FAIR	pFET	$V_{DG} < 40 \text{ В}; I_{GF} < 10 \text{ мА}; P_D < 300 \text{ мВт}; I_{OSS} < 16 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	D-S•G
62	DTC123YE	ROHM	Dnnp	$V_{CE0} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 33; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{11}/R_{21} < 2.2/10 \text{ кОм}$	SOT416,SC75A	B-E•C
62	DTC123YKA	ROHM	Dnnp	$V_{CE0} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 33; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{11}/R_{21} < 2.2/10 \text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E•C
62	DTC123YUA	ROHM	Dnnp	$V_{CE0} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 33; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{11}/R_{21} < 2.2/10 \text{ кОм}$	SOT323,SC70	B-E•C
624	FMMT624	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 125 \text{ В}; I_C < 1000 \text{ мА}; P_D < 625 \text{ мВт}; h_{21} > 300; .450; f_T > 155 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E•C
625	FMMT625	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 150 \text{ В}; I_C < 1000 \text{ мА}; P_D < 625 \text{ мВт}; h_{21} > 300; .450; f_T > 135 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E•C
62P	MMBFJ201	FAIR	nFET	$V_{DG} < 40 \text{ В}; I_{GF} < 50 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{OSS} < 1 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	S-D•G
62Q	MMBFJ202	FAIR	nFET	$V_{DG} < 40 \text{ В}; I_{GF} < 50 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{OSS} < 4.5 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	S-D•G
62T	MMBFJ271	FAIR	pFET	$V_{DG} < 30 \text{ В}; I_{GF} < 50 \text{ мА}; P_D < 225 \text{ мВт}; I_{OSS} < 50 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	D-S•G
62V	PZM62NB	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z=2 \text{ мА}) < 58.0 \dots 66.0 \text{ В}; Z_{T1}(I_Z=2 \text{ мА}) < 140 \text{ Ом}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
63	BAS40W	PHIL	shd	$V_A < 40 \text{ В}; I_A < 120 \text{ мА}; V_{F1}(I_A=1 \text{ мА}) < 380 \text{ мВ}; C_D < 5 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	A-n.c.-K
63Q	MMBFJ304	NS	nFET	$V_{DG} < 30 \text{ В}; I_{GF} < 50 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23,SOD23	D-S•G
63s	BAT64	INF	shd	$V_A < 40 \text{ В}; I_A < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_A=100 \text{ мА}) < 0.75 \text{ В}; I_S < 2 \text{ мкА}; C_D < 6 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
63s	BAT64W	INF	shd	$V_A < 40 \text{ В}; I_A < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_A=100 \text{ мА}) < 0.75 \text{ В}; I_S < 2 \text{ мкА}; C_D < 6 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1-n.c.-K
64	BAS4004W	PHIL	shd-2	$V_A < 40 \text{ В}; I_A < 120 \text{ мА}; V_{F1}(I_A=1 \text{ мА}) < 380 \text{ мВ}; C_D < 5 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1-K2-K1,A2
64	DTC114YE	ROHM	Dnnp	$V_{CE0} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 68; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{11}/R_{21} < 10/47 \text{ кОм}$	SOT416,SC75A	B-E•C
64	DTC114YKA	ROHM	Dnnp	$V_{CE0} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 68; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{11}/R_{21} < 10/47 \text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E•C
64	DTC114YUA	ROHM	Dnnp	$V_{CE0} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 68; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{11}/R_{21} < 10/47 \text{ кОм}$	SOT323,SC70	B-E•C
64s	BAT6404	SIEM	shd-2	$V_A < 40 \text{ В}; I_A < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_A=100 \text{ мА}) < 0.75 \text{ В}; I_S < 2 \text{ мкА}; C_D < 6 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
64s	BAT64-04	INF	shd-2	$V_A < 40 \text{ В}; I_A < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_A=100 \text{ мА}) < 0.75 \text{ В}; I_S < 2 \text{ мкА}; C_D < 6 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
64s	BAT64-04W	INF	shd-2	$V_A < 40 \text{ В}; I_A < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_A=100 \text{ мА}) < 0.75 \text{ В}; I_S < 2 \text{ мкА}; C_D < 6 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1-K2-K1,A2
65	BAS4005W	PHIL	shd-2	$V_A < 40 \text{ В}; I_A < 120 \text{ мА}; V_{F1}(I_A=1 \text{ мА}) < 380 \text{ мВ}; C_D < 5 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1-K2-K1,K2
65s	BAT6405	SIEM	shd-2	$V_A < 40 \text{ В}; I_A < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_A=100 \text{ мА}) < 0.75 \text{ В}; I_S < 2 \text{ мкА}; C_D < 6 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
65s	BAT64-05	INF	shd-2	$V_A < 40 \text{ В}; I_A < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_A=100 \text{ мА}) < 0.75 \text{ В}; I_S < 2 \text{ мкА}; C_D < 6 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
65s	BAT64-05W	INF	shd-2	$V_A < 40 \text{ В}; I_A < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_A=100 \text{ мА}) < 0.75 \text{ В}; I_S < 2 \text{ мкА}; C_D < 6 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1-A2-K1,K2
66	BAS4006W	PHIL	shd-2	$V_A < 40 \text{ В}; I_A < 120 \text{ мА}; V_{F1}(I_A=1 \text{ мА}) < 380 \text{ мВ}; C_D < 5 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	K1-K2-A1,A2
66s	BAT6406	SIEM	shd-2	$V_A < 40 \text{ В}; I_A < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_A=100 \text{ мА}) < 0.75 \text{ В}; I_S < 2 \text{ мкА}; C_D < 6 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
66s	BAT64-06	INF	shd-2	$V_A < 40 \text{ В}; I_A < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_A=100 \text{ мА}) < 0.75 \text{ В}; I_S < 2 \text{ мкА}; C_D < 6 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
66s	BAT64-06W	INF	shd-2	$V_A < 40 \text{ В}; I_A < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_A=100 \text{ мА}) < 0.75 \text{ В}; I_S < 2 \text{ мкА}; C_D < 6 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	K1-K2-A1,A2
68V	PZM68NB	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z=2 \text{ мА}) < 64.0 \dots 72.0 \text{ В}; Z_{T1}(I_Z=2 \text{ мА}) < 160 \text{ Ом}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
69	DTC114YE	MOT	Dnnp	$V_{CE0} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{21} > 68; f_T > 250 \text{ МГц}; R_{11}/R_{21} < 10/47 \text{ кОм}$	SOT416,SC75A	B-E•C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
69	DTC115TE	ROHM	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 150 мВт; h_{FE1} : 100...600; f_T : >250 МГц; $R_{\theta Jc}$: 100 К/ом	SOT416, SC75A	B-E-C
6A	BC817-16	CDIL	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 330 мВт; h_{FE1} : 100...250; f_T : >170 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6A	BC817-16	VISH	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 800 мА; P_D : 310 мВт; h_{FE1} : 100...250; f_T : >100 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6A	BC817-16LT1	MOT	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 300 мВт; h_{FE1} : 100...250; f_T : >200 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6A	BC817-16W	PHIL	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : 100...250; f_T : >100 МГц	SOT23, SC70	B-E-C
6A	DTA114EET1	MOT	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 150 мВт; h_{FE1} : >30; f_T : >250 МГц; $R_{\theta Jc}$: 10/10 К/ом	SOT416, SC75A	B-E-C
6A	MMBF4416	MOT	nFET	V_{DS} : 30 В; I_G : <10 мА; P_D : 300 мВт; NF : <4 дБ	SOT23, SOD23	D-S-G
6A	MUN2111T1	ON	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 246 мВт; h_{FE1} : >25; 10 К/ом/10 К/ом	SOT346, SC59	B-E-C
6A	MUN5111T1	ON	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : >35; 10 К/ом/10 К/ом	SOT323, SC70	B-E-C
6A2	MMBZ6V2AL	ON	dz-2	$V_{ZT}(I_Z=1 \text{ mA})$: 5.89...6.51 В; $V_{ZT}(I_Z=10 \text{ mA})$: <0.9 В	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
6A2	PZM6.2NB2A	PHIL	dz-2	$V_{ZT}(I_Z=5 \text{ mA})$: 6.06...6.33 В; $Z_{T1}(I_Z=5 \text{ mA})$: <10 Ом	SOT346, SC59	K1-K2-A1, A2
6A8	MMBZ6V9AL	ON	dz-2	$V_{ZT}(I_Z=1 \text{ mA})$: 6.46...7.14 В; $V_{ZT}(I_Z=10 \text{ mA})$: <0.9 В	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
6A8	PZM6.8NB2A	PHIL	dz-2	$V_{ZT}(I_Z=5 \text{ mA})$: 6.65...6.93 В; $Z_{T1}(I_Z=5 \text{ mA})$: <15 Ом	SOT346, SC59	K1-K2-A1, A2
6Ap	BC817-16	PHIL	nprn	V_{CE0} : 45 В; I_C : 500 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : 100...250; f_T : >80 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6AR	BC817-16R	PHIL	nprn	V_{CE0} : 45 В; I_C : 500 мА; P_D : 310 мВт; h_{FE1} : >250; f_T : >200 МГц	SOT23, SOD23	E-B-C
6As	BC817-16	SIEM	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 330 мВт; h_{FE1} : 100...250; f_T : >170 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6As	BC817-16W	SIEM	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : 100...250; f_T : >170 МГц	SOT23, SC70	B-E-C
6At	BC817-16	PHIL	nprn	V_{CE0} : 45 В; I_C : 500 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : 100...250; f_T : >80 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6AZ	BC817-16	ZETEX	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 330 мВт; h_{FE1} : 100...250; f_T : >200 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6B	BC817-25	CDIL	nprn	V_{CE0} : 45 В; I_C : 500 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : 160...400; f_T : >80 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6B	BC817-25	VISH	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 800 мА; P_D : 310 мВт; h_{FE1} : 160...400; f_T : >100 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6B	BC817-25LT1	MOT	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 300 мВт; h_{FE1} : 160...400; f_T : >200 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6B	BC817-25W	PHIL	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : 160...400; f_T : >100 МГц	SOT323, SC70	B-E-C
6B	DTA124EET1	MOT	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; $I_{C(max)}$: 100 мА; P_D : 150 мВт; h_{FE1} : >56; f_T : >250 МГц; $R_{\theta Jc}$: 22/22 К/ом	SOT416, SC75A	B-E-C
6B	MMBF5484	MOT	nFET	V_{DS} : 25 В; I_{GS} : 10 мА; P_D : 200 мВт; I_{DSS} : <5 мА	SOT23, SOD23	D-S-G
6B	MUN2112T1	ON	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 246 мВт; h_{FE1} : >60; 22 К/ом/22 К/ом	SOT346, SC59	B-E-C
6B	MUN5112T1	ON	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : >60; 22 К/ом/22 К/ом	SOT323, SC70	B-E-C
6BG	CMPP4416A	CSI	nFET	V_{DSS} : 35 В; I_{DSS} : 5...15 мА; $V_{GS(max)}$: 2.5...6 В; NF : 2 дБ	SOT23, SOD23	D-S-G
6Bp	BC817-25	PHIL	nprn	V_{CE0} : 45 В; I_C : 500 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : 160...400; f_T : >80 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6BR	BC817-25R	PHIL	nprn	V_{CE0} : 45 В; I_C : 500 мА; P_D : 310 мВт; h_{FE1} : >400; f_T : >200 МГц	SOT23, SOD23	E-B-C
6Bs	BC817-25	SIEM	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 330 мВт; h_{FE1} : 160...400; f_T : 170 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6Bs	BC817-25W	INF	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : 160...400; f_T : 170 МГц	SOT323, SC70	B-E-C
6BZ	BC817-25	ZETEX	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 330 мВт; h_{FE1} : 160...400; f_T : >200 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6C	BC817-40	CDIL	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 330 мВт; h_{FE1} : 250...630; f_T : >170 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6C	BC817-40	VISH	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 800 мА; P_D : 310 мВт; h_{FE1} : 250...630; f_T : >100 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6C	BC817-40LT1	MOT	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 300 мВт; h_{FE1} : 250...600; f_T : >200 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6C	BC817-40W	PHIL	nprn	V_{CE0} : 45 В; I_C : 500 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : 250...600; f_T : >100 МГц	SOT323, SC70	B-E-C
6C	DTA144EET1	MOT	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; $I_{C(max)}$: 100 мА; P_D : 150 мВт; h_{FE1} : >68; f_T : >250 МГц; $R_{\theta Jc}$: 47/47 К/ом	SOT416, SC75A	B-E-C
6C	MMBFU310LT1	MOT	nFET	V_{DS} : 25 В; I_{GS} : 10 мА; P_D : 225 мВт; I_{DSS} : <60 мА	SOT23, SOD23	D-S-G
6C	MUN2113T1	ON	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 246 мВт; h_{FE1} : >80; 47 К/ом/47 К/ом	SOT346, SC59	B-E-C
6C	MUN5113T1	ON	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : >80; 47 К/ом/47 К/ом	SOT323, SC70	B-E-C
6Cp	BC817-40	PHIL	nprn	V_{CE0} : 45 В; I_C : 500 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : 250...600; f_T : >80 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6CR	BC817-40R	PHIL	nprn	V_{CE0} : 45 В; I_C : 500 мА; P_D : 310 мВт; h_{FE1} : 600; f_T : >200 МГц	SOT23, SOD23	E-B-C
6Cs	BC817-40	SIEM	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 330 мВт; h_{FE1} : 250...630; f_T : 170 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6Cs	BC817-40W	INF	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : 250...630; f_T : 170 МГц	SOT323, SC70	B-E-C
6Ct	BC817-40	PHIL	nprn	V_{CE0} : 45 В; I_C : 500 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : 250...600; f_T : >80 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6CZ	BC817-40	ZETEX	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 330 мВт; h_{FE1} : 250...600; f_T : >200 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6D	BC817	CDIL	nprn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 330 мВт; h_{FE1} : 100...600; f_T : >200 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
6D	DTA114YET1	MOT	Dnpn	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 150 мВт; h_{FE1} : >68; f_T : >250 МГц; $R_{\theta Jc}$: 10/47 К/ом	SOT416, SC75A	B-E-C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
6D	MMBF5457	FAIR	nFET	$V_{DS} > 25 В; I_{GF} = 10 мА; P_D = 350 мВт; I_{GSS} < 5 мА$	SOT23, SOD23	S-D•G
6D	MUN2114T1	ON	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 246 мВт; h_{21} > 80; 10 кОм/47 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
6D	MUN5114T1	ON	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 80; 10 кОм/47 кОм$	SOT323, SC70	B•E•C
6D-	BC817W	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
6Dp	BC817	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 45 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 80 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6D1	BC817W	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
6DZ	BC817	ZETEX	nnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6E	BC818-16	CDIL	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 100...250; f_T > 170 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6E	BC818-16W	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 100...250; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
6E	DTA114TET1	MOT	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 250 МГц; R_1 = 10 кОм$	SOT416, SC75A	B•E•C
6E	FMMTA93R	ZETEX	rnpn	$V_{CE0} = 200 В; I_C = 200 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 30...150; f_T > 50 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6E	MMBF5460	MOT	pFET	$V_{DS} > 40 В; I_{GF} = 10 мА; P_D = 300 мВт; I_{GSS} < 5 мА$	SOT23, SOD23	D•S•G
6E	MMBF5460	FAIR	pFET	$V_{DS} > 40 В; I_{GF} = 10 мА; P_D = 300 мВт; I_{GSS} < 5 мА$	SOT23, SOD23	D•S•G
6E	MUN2115T1	ON	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 246 мВт; h_{21} > 160; R_1 = 10 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
6E	MUN5115T1	ON	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 160; R_1 = 10 кОм$	SOT323, SC70	B•E•C
6EP	BC818-16	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...250; f_T > 80 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6ER	BC818-16R	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 310 мВт; h_{21} = 250; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6Es	BC818-16	SIEM	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 100...250; f_T > 170 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6Es	BC818-16W	INF	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...250; f_T > 170 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
6E1	BC818-16	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...250; f_T > 80 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6EZ	BC818-16	ZETEX	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 100...250; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6F	BC818-25	CDIL	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 160...400; f_T > 170 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6F	BC818-25	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 160...400; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6F	BC818-25W	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 160...400; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
6F	DTA114TET1	MOT	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 250 МГц; R_1 = 4.7 кОм$	SOT416, SC75A	B•E•C
6F	MMBF4860	MOT	nFET	$V_{DS} > 30 В; I_G < 50 мА; P_D = 300 мВт$	SOT23, SOD23	D•S•G
6F	MUN2116T1	ON	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 246 мВт; h_{21} > 160; R_1 = 4.7 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
6F	MUN5116T1	ON	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 160; R_1 = 4.7 кОм$	SOT323, SC70	B•E•C
6Fp	BC818-25	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 160...400; f_T > 80 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6FR	BC818-25R	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 310 мВт; h_{21} = 400; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	E•B•C
6Fs	BC818-25	INF	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 160...400; f_T > 170 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6Fs	BC818-25W	INF	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 160...400; f_T > 170 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6FZ	BC818-25	ZETEX	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 160...400; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6FZ	BC818-25	ZETEX	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 160...400; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6G	BC818-40	CDIL	nnpn	$V_{CE0} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 250...600; f_T > 80 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6G	BC818-40W	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 250...600; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
6G	CMPF4393	CSI	nFET	$V_{GS} > 40 В; I_{GSS} = 5...30 мА; V_{DS(on)} = 0.5...3 В; R_{DS(on)} < 100 Ом; I_{GF} = 50 мА$	SOT23, SOD23	D•S•G
6G	FMV2103	ZETEX	bd	$V_A < 30 В; C_{4B} = 9...11 нФ; C_{2B}/C_{30B} = 2.6...3.3; Q > 400$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
6G	MMBF4393	FAIR	nFET	$V_{DS} > 30 В; I_{GF} = 50 мА; P_D = 350 мВт; R_{DS(on)} < 100 Ом$	SOT23, SOD23	D•S•G
6G	MMBF4393LT1	ON	nFET	$V_{DS} > 30 В; I_{GF} = 50 мА; P_D = 350 мВт; R_{DS(on)} < 100 Ом$	SOT23, SOD23	D•S•G
6G	MUN2130T1	ON	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 246 мВт; h_{21} > 3; 1 кОм/1 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
6G	MUN5130T1	ON	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 3; 1 кОм/1 кОм$	SOT323, SC70	B•E•C
6Gp	BC818-40	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 250...600; f_T > 80 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6GR	BC818-40R	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 310 мВт; h_{21} = 600; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	E•B•C
6Gs	BC818-40	INF	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 250...630; f_T > 170 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6Gs	BC818-40W	INF	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 250...630; f_T > 170 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
6Gt	BC818-40	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 250...600; f_T > 80 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6GZ	BC818-40	ZETEX	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 250...630; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6H	BC818	PHIL	nnpn	$V_{CE0} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 80 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
6H	BC818W	CDIL	nnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
6H	DTA123EE1	MOT	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 20; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 2.2/2.2 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
6H	FMMV2104	ZETEX	bd	$V_B < 30 \text{ В}; C_{4B} = 10.8 \dots 13.2 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{30B} = 2.6 \dots 3.3; Q > 400$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
6H	MMBF5486	MOT	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; I_{GR} = 10 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; I_{SS} < 20 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	D-S-G
6H	MUN2131T1	ON	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 246 \text{ мВт}; h_{FE1} > 8; 2.2 \text{ кОм}/2.2 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
6H	MUN5131T1	ON	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 8; 2.2 \text{ кОм}/2.2 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
6HD	BC818	PHIL	npn	$V_{CBO} = 25 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100 \dots 600; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
6HZ	BC818	ZETEX	npn	$V_{CBO} = 30 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100 \dots 600; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
6J	CMPP4391	CSI	nFET	$V_{DSS} > 40 \text{ В}; I_{DSS} = 50 \dots 150 \text{ мА}; V_{GS(off)} = 4 \dots 10 \text{ В}; R_{DS(on)} < 30 \text{ Ом}; t_{GFF} < 20 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	D-S-G
6J	DTA143EE1	MOT	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 20; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 4.7/4.7 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
6J	FMMV2105	ZETEX	bd	$V_B < 30 \text{ В}; C_{4B} = 13.5 \dots 16.5 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{30B} = 2.6 \dots 3.3; Q > 400$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
6J	MMBF4391	FAIR	nFET	$V_{DS} = 30 \text{ В}; I_{GR} = 50 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
6J	MMBF4391LT1	ON	nFET	$V_{DS} = 30 \text{ В}; I_{GR} = 50 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
6J	MUN2132T1	ON	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 246 \text{ мВт}; h_{FE1} > 15; 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
6J	MUN5132T1	ON	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 15; 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
6K	CMPP4392	CSI	nFET	$V_{DSS} > 40 \text{ В}; I_{DSS} = 25 \dots 75 \text{ мА}; V_{GS(off)} = 2 \dots 5 \text{ В}; R_{DS(on)} < 60 \text{ Ом}; t_{GFF} < 35 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	D-S-G
6K	DTA143ZE1	MOT	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 8; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 4.7/4.7 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
6K	MMBF4392	FAIR	nFET	$V_{DS} = 30 \text{ В}; I_{GR} = 50 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 60 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
6K	MMBF4392LT1	ON	nFET	$V_{DS} = 30 \text{ В}; I_{GR} = 50 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 60 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
6K	MUN2133T1	ON	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 246 \text{ мВт}; h_{FE1} > 80; 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
6K	MUN5133T1	ON	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 80; 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
6L	DTA124XET1	MOT	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 68; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 22/47 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
6L	FMMV2107	ZETEX	bd	$V_B < 30 \text{ В}; C_{4B} = 19.8 \dots 24.2 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{30B} = 2.7 \dots 3.3; Q > 350$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
6L	MMBF5459	FAIR	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; I_{GR} = 10 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; I_{SS} < 16 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	S-D-G
6L	MUN2134T1	ON	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 246 \text{ мВт}; h_{FE1} > 80; 22 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
6L	MUN5134T1	ON	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 80; 22 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
6M	DTA123JE1	MOT	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 80; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 2.2/4.7 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
6M	FMMV2108	ZETEX	bd	$V_B < 30 \text{ В}; C_{4B} = 24.3 \dots 29.7 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{30B} = 2.7 \dots 3.3; Q > 300$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
6M	MMBF5485	NS	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; I_{GR} = 10 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	D-S-G
6M	MUN5135T1	ON	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 80; 2.2 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
6N	DTA115EE1	MOT	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_{C(max)} = 100; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 82; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 100/100 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
6N	FMMV2109	ZETEX	bd	$V_B < 30 \text{ В}; C_{4B} = 29.3 \dots 36.3 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{30B} = 2.7 \dots 3.3; Q > 280$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
6N	MMBF4861	NS	nFET	$V_{DS} = 30 \text{ В}; P_D = 350 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 60 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
6N	MUN2136T1	ON	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 246 \text{ мВт}; h_{FE1} > 80; 100 \text{ кОм}/100 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
6N	MUN5136T1	ON	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 80; 100 \text{ кОм}/100 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
6P	BCX71HR	ZETEX	npn	$V_{CBO} = 45 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 180 \dots 310; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
6P	BCX71HR	PHIL	npn	$V_{CBO} = 45 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 180 \dots 310; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
6P	DTA144WET1	MOT	nFET	$V_{DS} = 50 \text{ В}; I_{C(max)} = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 56; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 47/22 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-C-E
6P	MMBFJ111	FAIR	nFET	$V_{DS} = 35 \text{ В}; I_{GR} = 50 \text{ мА}; P_D = 225 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	S-D-G
6P	MUN2137T1	ON	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 246 \text{ мВт}; h_{FE1} > 80; 4.7 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
6P	MUN5137T1	ON	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 80; 4.7 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
6Q	MMBFJ305	NS	nFET	$V_{DS} = 30 \text{ В}; I_{GR} = 50 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	D-S-G
6R	FMMV2101	ZETEX	bd	$V_B < 30 \text{ В}; C_{4B} = 6.1 \dots 7.5 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{30B} = 2.5 \dots 3.3; Q > 450$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
6R	MMBFJ112	FAIR	nFET	$V_{DS} = 35 \text{ В}; I_{GR} = 50 \text{ мА}; P_D = 225 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 50 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	S-D-G
6S	MMBFJ113	FAIR	nFET	$V_{DS} = 35 \text{ В}; I_{GR} = 50 \text{ мА}; P_D = 225 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 100 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	S-D-G
6T	BCV68GR	SIEM	npn	$V_{CBO} = 60 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 160 \dots 400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	C-B-E
6T	MMBFJ310	NS	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; I_{GR} = 50 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	D-S-G
6T	MUN2140T1	ON	Dpnp	$V_{CBO} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 246 \text{ мВт}; h_{FE1} > 120; R_1, R_2 = 4.7 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3
VMD3



SOT416
SOT523

SOT323
SOT346

SOT23-3
SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
613	1P570SB40	PHIL	shd	$V_A < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 380 мВ; C_{D0} < 5 нФ$	SOT323, SC70	A-n.c.-K
614	1P570SB44	PHIL	shd-2	$V_A < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 380 мВ; C_{D0} < 10 нФ$	SOT323, SC70	A1-K2-K1, A2
615	1P570SB45	PHIL	shd-2	$V_A < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 380 мВ; C_{D0} < 10 нФ$	SOT323, SC70	A1-A2-K1, K2
616	1P570SB46	PHIL	shd-2	$V_A < 40 В; I_F < 120 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 380 мВ; C_{D0} < 10 нФ$	SOT323, SC70	K1-K2-A1, A2
60U	MMBFJ309	NS	nFET	$V_{DS} < 25 В; I_{CF} < 50 мА; P_D < 350 мВт$	SOT23, SOD23	D-S-G
6V	BCW65CR	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 60 В; I_C < 800 мА; P_D < 330 мВт; h_{21} < 250...630; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
6V2	PZM6.2NB	PHIL	dz	$V_{Z}(I_Z = 5 мА) < 5.86...6.53 В; Z_{T1}(I_Z = 5 мА) < 10 Ом$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
6V8	PZM6.8NB	PHIL	dz	$V_{Z}(I_Z = 5 мА) < 6.47...7.14 В; Z_{T1}(I_Z = 5 мА) < 15 Ом$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
6W	BCW67CR	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 45 В; I_C < 800 мА; P_D < 330 мВт; h_{21} < 250...630; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
6W	MMBFJ175	FAIR	pFET	$V_{DS} < 30 В; I_{CF} < 50 мА; P_D < 225 мВт; R_{DS(on)} < 125 Ом$	SOT23, SOD23	D-S-G
6X	MMBFJ176	FAIR	pFET	$V_{DS} < 30 В; I_{CF} < 50 мА; P_D < 225 мВт; R_{DS(on)} < 250 Ом$	SOT23, SOD23	D-S-G
6Y	MMBFJ177	FAIR	pFET	$V_{DS} < 30 В; I_{CF} < 50 мА; P_D < 225 мВт; R_{DS(on)} < 300 Ом$	SOT23, SOD23	D-S-G
6Z	MMBF170LT1	MOT	nMOS	$V_{DS} < 60 В; I_D < 500 мА; P_D < 225 мВт$	SOT23, SOD23	G-S-D
7.5X	Q2C27.5	TOSH	dz	$V_{Z}(I_Z = 5 мА) < 7.00...7.90 В; I_L(V_A = 6.0 В) < 0.5 мкА; Z_{T1}(I_Z = 0.5 мА) < 120 Ом$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
702	ZN7002	VISH	nFET	$V_{DS} < 60 В; I_D < 115 мА; P_D < 200 мВт; V_{GS} < 2.5 В; C_{GS} < 60 пФ$	SOT23, SOD23	G-S-D
702W	L2N7002LT1	LRC	nFET	$V_{DS} < 60 В; I_D < 115 мА; P_D < 300 мВт; V_{GS(th)} < 1.2...2.5 В; C_{GS} < 50 пФ$	SOT23, SOD23	G-S-D
717	FMMT717	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 12 В; I_C < 2500 мА; P_D < 625 мВт$	SOT23, SOD23	B-E-C
718	FMMT718	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 20 В; I_C < 1500 мА; P_D < 625 мВт; h_{21} < 300...450; f_T > 180 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
720	FMMT720	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 40 В; I_C < 1500 мА; P_D < 625 мВт; h_{21} < 300...450; f_T > 190 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
722	FMMT722	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 70 В; I_C < 1500 мА; P_D < 625 мВт; h_{21} < 300...450; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
723	FMMT723	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 100 В; I_C < 1000 мА; P_D < 625 мВт; h_{21} < 300...450; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
73	BAS70	VISH	shd	$V_A < 70 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ; I_{RR} < 5 мС$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
73	BAS70	GS	shd	$V_A < 70 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ; I_{RR} < 5 мС$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
73	BAS70	DIOT	shd	$V_A < 70 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ; I_{RR} < 5 мС$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
73	BAS70	MCS	shd	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ; I_{RR} < 5 мС$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
73-	BAS70W	PHIL	shd	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 410 мВ; C_{D0} < 2 нФ$	SOT323, SC70	A-n.c.-K
73p	BAS70	PHIL	shd	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 410 мВ; C_{D0} < 2 нФ$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
73p	BAS70W	PHIL	shd	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 410 мВ; C_{D0} < 2 нФ$	SOT323, SC70	A-n.c.-K
73s	BAS70	INF	shd	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
73t	BAS70W	PHIL	shd	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 410 мВ; C_{D0} < 2 нФ$	SOT323, SC70	A-n.c.-K
74	BAS7004	VISH	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ; I_{RR} < 5 мС$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
74	BAS70-04	GS	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ; I_{RR} < 5 мС$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
74	BAS70-04	DIOT	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ; I_{RR} < 5 мС$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
74	BAS70-04	MCS	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ; I_{RR} < 5 мС$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
74	DTA114WE	ROHM	Dnpn	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} > 24; f_T > 250 МГц; R_{F1}/R_{F2} < 10/4.7 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
74	DTA114WKA	ROHM	Dnpn	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 24; f_T > 250 МГц; R_{F1}/R_{F2} < 10/4.7 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
74	DTA114WUA	ROHM	Dnpn	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 24; f_T > 250 МГц; R_{F1}/R_{F2} < 10/4.7 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
74-	BAS70-04W	PHIL	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 410 мВ; C_{D0} < 2 нФ$	SOT323, SC70	A1-K2-K1, A2
74p	BAS7004	PHIL	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 410 мВ; C_{D0} < 2 нФ$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
74p	BAS7004W	PHIL	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 410 мВ; C_{D0} < 2 нФ$	SOT323, SC70	A1-K2-K1, A2
74s	BAS7004	SIEM	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 2.0 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
74s	BAS70-04	INF	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
74s	BAS70-04T	INF	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ$	SOT416, SC75A	A1-K2-K1, A2
74s	BAS7004W	SIEM	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ$	SOT323, SC70	A1-K2-K1, A2
74s	BAS70-04W	INF	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ$	SOT323, SC70	A1-K2-K1, A2
74t	BAS70-04W	PHIL	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 70 мА; V_{F1}(I_F = 1 мА) < 410 мВ; C_{D0} < 2 нФ$	SOT323, SC70	A1-K2-K1, A2
75	BAS7005	VISH	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ; I_{RR} < 5 мС$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
75	BAS70-05	GS	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ; I_{RR} < 5 мС$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
75	BAS70-05	DIOT	shd-2	$V_A < 70 В; I_F < 200 мА; V_{F1}(I_F = 15 мА) < 1.0 В; I_S < 0.1 мкА; C_{D0} < 2.0 нФ; I_{RR} < 5 мС$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPAK TSFP-3 VMD3

Код	Типонаимал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
75	BAS70-05	MCS	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=15 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_B < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
75-	BAS70-05W	PHIL	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=1 \text{ мА})} < 410 \text{ мВ}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
75p	BAS70-05	PHIL	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=1 \text{ мА})} < 410 \text{ мВ}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
75p	BAS7005W	PHIL	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=1 \text{ мА})} < 410 \text{ мВ}; C_D < 2 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 0.1 \text{ нс}$	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
75s	BAS7005	SIEM	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=15 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_B < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
75s	BAS70-05	INF	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=15 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_B < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
75s	BAS7005W	SIEM	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=15 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_B < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
75s	BAS70-05W	INF	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=15 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_B < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
75t	BAS70-05	PHIL	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=1 \text{ мА})} < 410 \text{ мВ}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
75t	BAS70-05W	PHIL	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=1 \text{ мА})} < 410 \text{ мВ}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1•A2•K1,K2
75V	PZM75NB	PHIL	dz	$V_{F(I_{D1}=2 \text{ мА})} = 70.0...79.0 \text{ В}; Z_{T1(I_{D1}=2 \text{ мА})} < 175 \text{ Ом}$	SOT346,SC59	A•n.c.•K
76	BAS7006	WISH	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F(I_C=15 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_B < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76	BAS70-06	GS	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F(I_C=15 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_B < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76	BAS70-06	DIOT	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F(I_C=15 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_B < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76	BAS70-06	MCS	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=15 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_B < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76	DTA144WE	ROHM	Dnpn	$V_{\text{СВЭ}} = 50 \text{ В}; I_{\text{C(ном)}} = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 56; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 47/22 \text{ кОм}$	SOT416,SC75A	B•E•C
76	DTA144WKA	ROHM	Dnpn	$V_{\text{СВЭ}} = 50 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 56; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 47/22 \text{ кОм}$	SOT346,SC59	B•E•C
76	DTA144WJA	ROHM	Dnpn	$V_{\text{СВЭ}} = 50 \text{ В}; I_{\text{C(ном)}} = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 56; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 47/22 \text{ кОм}$	SOT323,SC70	B•E•C
76-	BAS70-06W	PHIL	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=1 \text{ мА})} < 410 \text{ мВ}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
76p	BAS70-06	PHIL	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=1 \text{ мА})} < 410 \text{ мВ}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76p	BAS7006W	PHIL	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=1 \text{ мА})} < 410 \text{ мВ}; C_D < 2 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 0.1 \text{ нс}$	SOT323,SC70	K1•K2•A2,A1
76s	BAS7006	SIEM	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=15 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_B < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76s	BAS70-06	INF	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=15 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_B < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76s	BAS7006W	SIEM	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=15 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_B < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
76s	BAS70-06W	INF	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=15 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_B < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
76t	BAS70-06	PHIL	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=1 \text{ мА})} < 410 \text{ мВ}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
76t	BAS70-06W	PHIL	shd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 70 \text{ мА}; V_{F(I_C=1 \text{ мА})} < 410 \text{ мВ}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
7A	MMBR901LT1	MOT	npn	$V_{\text{СВЭ}} = 25 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 30...200$	SOT23,SOD23	B•E•C
7A	MMBR901LT3	MOT	npn	$V_{\text{СВЭ}} = 25 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 30...200$	SOT23,SOD23	B•E•C
7A5	PZM7-5NB2A	PHIL	dzx2	$V_{F(I_{D1}=5 \text{ мА})} = 7.28...7.60 \text{ В}; Z_{T1(I_{D1}=5 \text{ мА})} < 10 \text{ Ом}$	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
7B	MMBR920LT2	MOT	npn	$V_{\text{СВЭ}} = 20 \text{ В}; I_C = 35 \text{ мА}; P_D = 268 \text{ мВт}; h_{21} = 25...250; f_T = 4500 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
7D	HD4A	ZETEX	fid-2	$V_B < 35 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; V_{F(I_C=10 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_B < 1.0 \text{ мкА}; C_D < 4.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 6 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
7D	MMBR931LT1	MOT	npn	$V_{\text{СВЭ}} = 10 \text{ В}; I_C = 5 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 50...150$	SOT23,SOD23	B•E•C
7E	FMMTA42R	ZETEX	npn	$V_{\text{СВЭ}} = 300 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
7E	MMBR2060	MOT	npn	$V_{\text{СЭ}} = 30 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; f_T = 1 \text{ ГГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
7F	MMBR945LT1	MOT	pnp	$V_{\text{СЭ}} = 30 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 278 \text{ мВт}; f_T = 1.2 \text{ ГГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
7G	MMBR5031LT1	MOT	npn	$V_{\text{СВЭ}} = 15 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 25...300; f_T = 1000 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
7H	KST1579	SAMS	npn	$V_{\text{СВЭ}} = 20 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} > 25; f_T > 900 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
7H	MMBR5179LT1	MOT	npn	$V_{\text{СВЭ}} = 20 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 375 \text{ мВт}; h_{21} > 25; f_T = 1400 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
7J	FMMT38C	ZETEX	npn	$V_{\text{СВЭ}} = 80 \text{ В}; I_C = 300 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} > 5000$	SOT23,SOD23	B•E•C
7K	MMBR2857LT1	MOT	npn	$V_{\text{СЭ}} = 15 \text{ В}; I_C = 40 \text{ мА}; f_T = 4 \text{ ГГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
7M	BCW66HR	ZETEX	npn	$V_{\text{СВЭ}} = 75 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 250...630; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
7M	MMBR521LT1	MOT	pnnp	$V_{\text{СВЭ}} = 20 \text{ В}; I_C = 70 \text{ мА}; P_D = 333 \text{ мВт}; h_{21} = 25...125; f_T = 3400 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
7N	BCW66HR	ZETEX	pnnp	$V_{\text{СВЭ}} = 60 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 250...630; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
7N	MMBR941BLT1	MOT	npn	$V_{\text{СВЭ}} = 20 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 100...200; f_T = 8000 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
7N	MMBR941BLT3	MOT	npn	$V_{\text{СВЭ}} = 20 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 100...200; f_T = 8000 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
7P	BCW66FR	ZETEX	npn	$V_{\text{СВЭ}} = 75 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 100...250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
7P	BCW66FR	SGS	npn	$V_{\text{СВЭ}} = 75 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 100...250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	C•B•E
7P	MMBR911LT1	MOT	npn	$V_{\text{СВЭ}} = 20 \text{ В}; I_C = 60 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 30...200; f_T = 6000 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
7R	MMBR536	MOT	pnnp	$V_{\text{СВЭ}} = 10 \text{ В}; I_C = 10 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	B•E•C

**SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3**

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
7T	BCW68FR	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 100...250$; $f_T > 100$ МГц	SOT23,SOD23	B-E-C
7V5	PZM7_5NB	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 5$ мА) = 7.06...7.84 В; $Z_{T1}(I_{ZT} = 5$ мА) < 10 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
7X	MMBR51LT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 20$ В; $I_C = 80$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 50...300$; $f_T = 8000$ МГц	SOT23,SOD23	B-E-C
7Y	MMBR941LT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 20$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 50...200$; $f_T = 8000$ МГц	SOT23,SOD23	B-E-C
7Y	MMBR941LT3	MOT	npn	$V_{CE0} = 20$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 50...250$; $f_T = 8000$ МГц	SOT23,SOD23	B-E-C
-7Y	PDTB123YT	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} > 70$; $2,2$ кОм/10 кОм	SOT23,SOD23	B-E-C
7Z	MMBR951LT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 20$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 322$ мВт; $h_{21} = 50...200$; $f_T = 8000$ МГц	SOT23,SOD23	B-E-C
8.2	01BZ48.2	TOSH	dz2-z	$V_{ZT}(I_Z = 5$ мА) = 7.7...8.7 В; $I_{S1}(V_{S1} = 6.5$ В) < 0.5 мкА	SOT323,SC70	K1-K2-A1,A2
8.2X	02CZ8.2	TOSH	dz	$V_{ZT}(I_Z = 5$ мА) = 7.70...8.70 В; $I_{S1}(V_{S1} = 6.5$ В) < 0.5 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 0.5$ мА) < 120 Ом	SOT346,SC59	A-n.c.-K
81A	FMMZ5250	ZETEX	dz	$V_Z = 20$ В; $Z_{T1}(I_{ZT} = 6.2$ мА) = 25 Ом	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81A	PMBZ5250B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 6.2$ мА) = 20 В; $I_{S1}(V_{S1} = 15.0$ В) < 0.1 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 6.2$ мА) < 600 Ом; $I_{ZM} = 200$ мА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81A	TMPZ5250	ALLEG	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 6.2$ мА) = 19.0...21.0 В; $I_{S1}(V_{S1} = 15.0$ В) < 0.1 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 6.2$ мА) < 25 Ом	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81A	MMBZ5250B	VISH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 6.2$ мА) = 19.0...21.0 В; $I_{S1} < 0.1$ мкА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81A	MMBZ5250BLT1	ON	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 6.2$ мА) = 19.0...21.0 В; $I_{S1} < 0.1$ мкА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81B	FMMZ5251	ZETEX	dz	$V_Z = 22$ В; $Z_{T1}(I_{ZT} = 5.6$ мА) = 29 Ом	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81B	PMBZ5251B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 5.6$ мА) = 22 В; $I_{S1}(V_{S1} = 17$ В) < 0.1 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 5.6$ мА) < 600 Ом; $I_{ZM} = 200$ мА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81B	TMPZ5251	ALLEG	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 5.5$ мА) = 20.9...23.1 В; $I_{S1}(V_{S1} = 17.0$ В) < 0.1 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 5.5$ мА) < 29 Ом	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81B	MMBZ5251B	VISH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 5.6$ мА) = 20.9...23.1 В; $I_{S1} < 0.1$ мкА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81B	MMBZ5251BLT1	ON	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 5.6$ мА) = 20.9...23.1 В; $I_{S1} < 0.1$ мкА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81C	FMMZ5252	ZETEX	dz	$V_Z = 24$ В; $Z_{T1}(I_{ZT} = 5.2$ мА) = 33 Ом	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81C	PMBZ5252B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 5.2$ мА) = 24 В; $I_{S1}(V_{S1} = 18$ В) < 0.1 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 5.2$ мА) < 600 Ом; $I_{ZM} = 200$ мА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81C	TMPZ5252	ALLEG	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 5.2$ мА) = 22.8...25.2 В; $I_{S1}(V_{S1} = 18.0$ В) < 0.1 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 5.2$ мА) < 33 Ом	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81C	MMBZ5252B	VISH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 5.2$ мА) = 22.8...25.2 В; $I_{S1} < 0.1$ мкА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81C	MMBZ5252BLT1	ON	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 5.2$ мА) = 22.8...25.2 В; $I_{S1} < 0.1$ мкА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81D	FMMZ5253	ZETEX	dz	$V_Z = 25$ В; $Z_{T1}(I_{ZT} = 5$ мА) = 35 Ом	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81D	PMBZ5253B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 5.0$ мА) = 25 В; $I_{S1}(V_{S1} = 19$ В) < 0.1 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 5.0$ мА) < 600 Ом; $I_{ZM} = 200$ мА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81D	TMPZ5253	ALLEG	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 5.0$ мА) = 23.8...26.3 В; $I_{S1}(V_{S1} = 19.0$ В) < 0.1 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 5.0$ мА) < 35 Ом	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81D	MMBZ5253B	VISH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 5.0$ мА) = 23.75...26.25 В; $I_{S1} < 0.1$ мкА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81D	MMBZ5253BLT1	ON	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 5.0$ мА) = 23.75...26.25 В; $I_{S1} < 0.1$ мкА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81E	FMMZ5254	ZETEX	dz	$V_Z = 27$ В; $Z_{T1}(I_{ZT} = 4.6$ мА) = 41 Ом	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81E	PMBZ5254B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 4.6$ мА) = 27 В; $I_{S1}(V_{S1} = 21$ В) < 0.1 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 4.6$ мА) < 600 Ом; $I_{ZM} = 200$ мА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81E	TMPZ5254	ALLEG	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 4.6$ мА) = 25.7...28.4 В; $I_{S1}(V_{S1} = 21.0$ В) < 0.1 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 4.6$ мА) < 41 Ом	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81E	MMBZ5254B	VISH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 5.0$ мА) = 25.65...28.35 В; $I_{S1} < 0.1$ мкА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81E	MMBZ5254BLT1	ON	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 5.0$ мА) = 25.65...28.35 В; $I_{S1} < 0.1$ мкА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81F	FMMZ5255	ZETEX	dz	$V_Z = 28$ В; $Z_{T1}(I_{ZT} = 4.5$ мА) = 44 Ом	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81F	PMBZ5255B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 4.5$ мА) = 28 В; $I_{S1}(V_{S1} = 21$ В) < 0.1 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 4.5$ мА) < 600 Ом; $I_{ZM} = 200$ мА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81F	TMPZ5255	ALLEG	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 4.5$ мА) = 26.6...29.4 В; $I_{S1}(V_{S1} = 21.0$ В) < 0.1 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 4.5$ мА) < 44 Ом	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81F	MMBZ5255B	VISH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 4.5$ мА) = 26.6...29.4 В; $I_{S1} < 0.1$ мкА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81F	MMBZ5255BLT1	ON	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 4.5$ мА) = 26.6...29.4 В; $I_{S1} < 0.1$ мкА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81G	FMMZ5256	ZETEX	dz	$V_Z = 30$ В; $Z_{T1}(I_{ZT} = 4.2$ мА) = 49 Ом	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81G	PMBZ5256B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT} = 4.2$ мА) = 30 В; $I_{S1}(V_{S1} = 23$ В) < 0.1 мкА; $Z_{T1}(I_{ZT} = 4.2$ мА) < 600 Ом; $I_{ZM} = 200$ мА	SOT23,SOD23	A-n.c.-K



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
81G	TMPZ5256	ALLEG	dz	$V_{21}(I_{21}=4.2 \text{ mA})=28.5...31.5 \text{ B}; I_1(V_{21}=23.0 \text{ B}) < 0.1 \text{ мкА};$ $Z_{21}(I_{21}=4.2 \text{ mA}) < 49 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81G	MMBZ5256B	VISH	dz	$V_2(I_{21}=4.2 \text{ mA})=28.5...31.5 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81G	MMBZ5256BLT1	ON	dz	$V_2(I_{21}=4.2 \text{ mA})=28.5...31.5 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81H	FMMZ5257	ZETEX	dz	$V_2=33 \text{ B}; Z_{21}(I_2=3.8 \text{ mA})=58 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81H	PMBZ5257B	PHIL	dz	$V_2(I_{21}=3.8 \text{ mA})=33 \text{ B}; I_1(V_{21}=25 \text{ B}) < 0.1 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{21}=3.8 \text{ mA}) < 600 \text{ Ом};$ $I_{2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81H	TMPZ5257	ALLEG	dz	$V_2(I_{21}=3.8 \text{ mA})=31.4...34.7 \text{ B}; I_1(V_{21}=25.0 \text{ B}) < 0.1 \text{ мкА};$ $Z_{21}(I_{21}=3.8 \text{ mA}) < 58 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81H	MMBZ5257B	VISH	dz	$V_2(I_{21}=3.8 \text{ mA})=31.35...34.65 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81H	MMBZ5257BLT1	ON	dz	$V_2(I_{21}=3.8 \text{ mA})=31.35...34.65 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81J	MMBZ5259B	VISH	dz	$V_2(I_{21}=3.4 \text{ mA})=34.2...37.8 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81J	MMBZ5259BLT1	ON	dz	$V_2(I_{21}=3.4 \text{ mA})=34.2...37.8 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81K	MMBZ5259B	VISH	dz	$V_2(I_{21}=3.2 \text{ mA})=37.05...41.0 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81K	MMBZ5259BLT1	ON	dz	$V_2(I_{21}=3.2 \text{ mA})=37.05...41.0 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81L	MMBZ5260BLT1	ON	dz	$V_2(I_{21}=3 \text{ mA})=40.85...45.15 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81M	MMBZ5261B	VISH	dz	$V_2(I_{21}=2.7 \text{ mA})=44.65...49.35 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81M	MMBZ5261BLT1	ON	dz	$V_2(I_{21}=2.7 \text{ mA})=44.65...49.35 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81N	MMBZ5262B	VISH	dz	$V_2(I_{21}=2.5 \text{ mA})=48.45...53.55 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81N	MMBZ5262BLT1	ON	dz	$V_2(I_{21}=2.5 \text{ mA})=48.45...53.55 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81P	MMBZ5263B	VISH	dz	$V_2(I_{21}=2.2 \text{ mA})=53.20...58.80 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81P	MMBZ5263BLT1	ON	dz	$V_2(I_{21}=2.2 \text{ mA})=53.20...58.80 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81Q	MMBZ5264B	VISH	dz	$V_2(I_{21}=2.1 \text{ mA})=57.00...63.00 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81Q	MMBZ5264BLT1	ON	dz	$V_2(I_{21}=2.1 \text{ mA})=57.00...63.00 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81R	MMBZ5265B	VISH	dz	$V_2(I_{21}=2 \text{ mA})=58.90...65.10 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81R	MMBZ5265BLT1	ON	dz	$V_2(I_{21}=2 \text{ mA})=58.90...65.10 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81S	MMBZ5266B	VISH	dz	$V_2(I_{21}=1.8 \text{ mA})=64.60...71.40 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81S	MMBZ5266BLT1	ON	dz	$V_2(I_{21}=1.8 \text{ mA})=64.60...71.40 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81T	MMBZ5267B	VISH	dz	$V_2(I_{21}=1.7 \text{ mA})=71.25...78.75 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81T	MMBZ5267BLT1	ON	dz	$V_2(I_{21}=1.7 \text{ mA})=71.25...78.75 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81U	MMBZ5268BLT1	ON	dz	$V_2(I_{21}=1.5 \text{ mA})=77.90...86.10 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81V	MMBZ5269BLT1	ON	dz	$V_2(I_{21}=1.4 \text{ mA})=82.65...91.35 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
81W	MMBZ5270BLT1	ON	dz	$V_2(I_{21}=1.4 \text{ mA})=86.45...95.55 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
83	BAT68	SIEM	shd	$V_2 < 8 \text{ B}; I_2 < 130 \text{ mA}; V_{F1}(I_2=10 \text{ mA}) < 0.5 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}; C_0 < 1.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
83s	BAT68	INF	shd	$V_2 < 8 \text{ B}; I_2 < 130 \text{ mA}; V_{F1}(I_2=10 \text{ mA}) < 0.5 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}; C_0 < 1.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
83s	BAT68W	INF	shd-2	$V_2 < 8 \text{ B}; I_2 < 130 \text{ mA}; V_{F1}(I_2=10 \text{ mA}) < 0.5 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}; C_0 < 1.0 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1-n.c.-K
84	BAT6804	SIEM	shd-2	$V_2 < 8 \text{ B}; I_2 < 130 \text{ mA}; V_{F1}(I_2=10 \text{ mA}) < 0.5 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}; C_0 < 1.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
84	DTC114WE	ROHM	Dnnp	$V_{CE0}=50 \text{ B}; I_2=100 \text{ mA}; P_0=150 \text{ мВт}; h_{21} > 24; f_T > 250 \text{ МГц};$ $R_1/R_2=10/4.7 \text{ кОм}$	SOT416,SC75A	B-E-C
84	DTC114WKA	ROHM	Dnnp	$V_{CE0}=50 \text{ B}; I_2=100 \text{ mA}; P_0=200 \text{ мВт}; h_{21} > 24; f_T > 250 \text{ МГц};$ $R_1/R_2=10/4.7 \text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
84	DTC114WUA	ROHM	Dnnp	$V_{CE0}=50 \text{ B}; I_2=100 \text{ mA}; P_0=200 \text{ мВт}; h_{21} > 24; f_T > 250 \text{ МГц};$ $R_1/R_2=10/4.7 \text{ кОм}$	SOT323,SC70	B-E-C
84s	BAT68-04	INF	shd-2	$V_2 < 8 \text{ B}; I_2 < 130 \text{ mA}; V_{F1}(I_2=10 \text{ mA}) < 0.5 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}; C_0 < 1.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
84s	BAT68-04W	INF	shd-2	$V_2 < 8 \text{ B}; I_2 < 130 \text{ mA}; V_{F1}(I_2=10 \text{ mA}) < 0.5 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}; C_0 < 1.0 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1-K2-K1,A2
85	BAT6805	SIEM	shd-2	$V_2 < 8 \text{ B}; I_2 < 130 \text{ mA}; V_{F1}(I_2=10 \text{ mA}) < 0.5 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}; C_0 < 1.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
85A	MMBD1701A	FAIR	dl	$V_2 < 30 \text{ B}; I_2=50 \text{ mA}; V_{F1}(I_2=50 \text{ mA}) < 1.1 \text{ B}; C_0 < 1 \text{ нФ}; t_{RR} < 1 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
85s	BAT68-05	INF	shd-2	$V_2 < 8 \text{ B}; I_2 < 130 \text{ mA}; V_{F1}(I_2=10 \text{ mA}) < 0.5 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}; C_0 < 1.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
85s	BAT68-05W	INF	shd-2	$V_2 < 8 \text{ B}; I_2 < 130 \text{ mA}; V_{F1}(I_2=10 \text{ mA}) < 0.5 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}; C_0 < 1.0 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1-A2-K1,K2
86	BAT6806	SIEM	shd-2	$V_2 < 8 \text{ B}; I_2 < 130 \text{ mA}; V_{F1}(I_2=10 \text{ mA}) < 0.5 \text{ B}; I_2 < 0.1 \text{ мкА}; C_0 < 1.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
86	DTC144WE	ROHM	Dnnp	$V_{CE0}=50 \text{ B}; I_2(I_{CM2})=100 \text{ mA}; P_0=150 \text{ мВт}; h_{21} > 56; f_T > 250 \text{ МГц};$ $R_1/R_2=47/22 \text{ кОм}$	SOT416,SC75A	B-E-C
86	DTC144WKA	ROHM	Dnnp	$V_{CE0}=50 \text{ B}; I_2=30 \text{ mA}; P_0=200 \text{ мВт}; h_{21} > 56; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2=47/22 \text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C

**SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3**

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
86	DTC144WUA	ROHM	Dnpr	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_{C\text{max}}=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>56; f_T>250\text{ МГц}; R_{\theta J/P_2}=47/22\text{ К/ОМ}$	SOT323,SC70	B•E•C
86s	BAT68-06	INF	shd-2	$V_{A<8}\text{ В}; I_{A<130}\text{ мА}; V_{F(I_{A<10}\text{ мА})}<0.5\text{ В}; I_{A<0.1}\text{ мкА}; C_D<1.0\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
86s	BAT68-06W	INF	shd-2	$V_{A<8}\text{ В}; I_{A<130}\text{ мА}; V_{F(I_{A<10}\text{ мА})}<0.5\text{ В}; I_{A<0.1}\text{ мкА}; C_D<1.0\text{ нФ}$	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
87A	MMBD1703A	FAIR	di-2	$V_{A<30}\text{ В}; I_{A<50}\text{ мА}; V_{F(I_{A<50}\text{ мА})}<1.1\text{ В}; C_D<1\text{ нФ}; t_{RR}<1\text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
88A	MMBD1704A	FAIR	di-2	$V_{A<30}\text{ В}; I_{A<50}\text{ мА}; V_{F(I_{A<50}\text{ мА})}<1.1\text{ В}; C_D<1\text{ нФ}; t_{RR}<1\text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
89A	MMBD1705A	FAIR	di-2	$V_{A<30}\text{ В}; I_{A<50}\text{ мА}; V_{F(I_{A<50}\text{ мА})}<1.1\text{ В}; C_D<1\text{ нФ}; t_{RR}<1\text{ нс}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
8A	2DA1774Q	DIODS	pnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>120...270; f_T=140\text{ МГц}$	SOT523	B•E•C
8A	DTC114EET1	MOT	Dnprn	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>30; f_T>250\text{ МГц}; R_{\theta J/P_2}=10/10\text{ К/ОМ}$	SOT416,SC75A	B•E•C
8A	MUN2211T1	ON	Dnprn	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=230\text{ мВт}; h_{21}>35; 10\text{ К/ОМ}/10\text{ К/ОМ}$	SOT346,SC59	B•E•C
8A	MUN5211T1	ON	Dnprn	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>35; 10\text{ К/ОМ}/10\text{ К/ОМ}$	SOT323,SC70	B•E•C
8A	MMB52226B	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT}=20\text{ мА})}=3.13...3.47\text{ В}; I_{ZT}<25\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K
8A	MMB52226BLT1	ON	dz	$V_{Z(I_{ZT}=20\text{ мА})}=3.13...3.47\text{ В}; I_{ZT}<25\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K
8A2	PZM8.2NB2A	PHIL	dz-2	$V_{Z(I_{ZT}=5\text{ мА})}=8.02...8.36\text{ В}; Z_{T(I_{ZT}=5\text{ мА})}<10\text{ Ом}$	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
8AA	BC846A	SAMS	nprn	$V_{CE0}=80\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=310\text{ мВт}; h_{21}>110...220; f_T>300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
8AA	BC846A	FAIR	nprn	$V_{CE0}=80\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>110...220; f_T>300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
8AAx	STM809L	STM	mrc	$V_{TR}=4.63\text{ В}; V_{D0}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<15\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	VSS-RST•V _{CC}
8AB	BC846B	SAMS	nprn	$V_{CE0}=80\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=310\text{ мВт}; h_{21}>200...450; f_T>300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
8AB	BC846B	FAIR	nprn	$V_{CE0}=80\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>200...450; f_T>300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
8ABx	STM809M	STM	mrc	$V_{TR}=4.38\text{ В}; V_{D0}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<15\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	VSS-RST•V _{CC}
8AC	BC846C	SAMS	nprn	$V_{CE0}=80\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=310\text{ мВт}; h_{21}>420...800; f_T>300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
8AC	BC846C	FAIR	nprn	$V_{CE0}=80\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=310\text{ мВт}; h_{21}>420...800; f_T>300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
8ACx	STM809T	STM	mrc	$V_{TR}=3.08\text{ В}; V_{D0}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<15\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	VSS-RST•V _{CC}
8ADx	STM809S	STM	mrc	$V_{TR}=2.93\text{ В}; V_{D0}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<15\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	VSS-RST•V _{CC}
8AEx	STM809R	STM	mrc	$V_{TR}=2.63\text{ В}; V_{D0}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<15\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	VSS-RST•V _{CC}
8AFx	STM810L	STM	mrc	$V_{TR}=4.63\text{ В}; V_{D0}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<15\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	VSS-RST•V _{CC}
8AGx	STM810M	STM	mrc	$V_{TR}=4.38\text{ В}; V_{D0}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<15\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	VSS-RST•V _{CC}
8AHx	STM810T	STM	mrc	$V_{TR}=3.08\text{ В}; V_{D0}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<15\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	VSS-RST•V _{CC}
8AJx	STM810S	STM	mrc	$V_{TR}=2.93\text{ В}; V_{D0}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<15\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	VSS-RST•V _{CC}
8AKx	STM810R	STM	mrc	$V_{TR}=2.63\text{ В}; V_{D0}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<15\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	VSS-RST•V _{CC}
8B	2DA1774R	DIODS	pnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>180...390; f_T=140\text{ МГц}$	SOT523	B•E•C
8B	DTC124EET1	MOT	Dnprn	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_{C\text{max}}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>56; f_T>250\text{ МГц}; R_{\theta J/P_2}=22/22\text{ К/ОМ}$	SOT416,SC75A	B•E•C
8B	MUN2212T1	ON	Dnprn	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=230\text{ мВт}; h_{21}>60; 22\text{ К/ОМ}/22\text{ К/ОМ}$	SOT346,SC59	B•E•C
8B	MUN5212T1	ON	Dnprn	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>60; 22\text{ К/ОМ}/22\text{ К/ОМ}$	SOT323,SC70	B•E•C
8B	MMB52227B	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT}=20\text{ мА})}=3.42...3.78\text{ В}; I_{ZT}<15\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K
8B	MMB52227BLT1	ON	dz	$V_{Z(I_{ZT}=20\text{ мА})}=3.42...3.78\text{ В}; I_{ZT}<15\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K
8BA	BC847A	FAIR	nprn	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; h_{21}>110...220; f_T>100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
8BB	BC847B	SAMS	nprn	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=310\text{ мВт}; h_{21}>200...450; f_T>300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
8BB	BC847B	FAIR	nprn	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=310\text{ мВт}; h_{21}>200...450; f_T>300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
8BC	BC847C	SAMS	nprn	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=310\text{ мВт}; h_{21}>420...800; f_T>300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
8BC	BC847C	FAIR	nprn	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=310\text{ мВт}; h_{21}>420...800; f_T>300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
8C	2DA1774S	DIODS	pnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>270...560; f_T=140\text{ МГц}$	SOT523	B•E•C
8C	DTC144EET1	MOT	Dnprn	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_{C\text{max}}=100; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>68; f_T>250\text{ МГц}; R_{\theta J/P_2}=47/47\text{ К/ОМ}$	SOT416,SC75A	B•E•C
8C	MUN2213T1	ON	Dnprn	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=230\text{ мВт}; h_{21}>80; 47\text{ К/ОМ}/47\text{ К/ОМ}$	SOT346,SC59	B•E•C
8C	MUN5213T1	ON	Dnprn	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>80; 47\text{ К/ОМ}/47\text{ К/ОМ}$	SOT323,SC70	B•E•C
8C	MMB52228B	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT}=20\text{ мА})}=3.70...4.10\text{ В}; I_{ZT}<10\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K
8C	MMB52228BLT1	ON	dz	$V_{Z(I_{ZT}=20\text{ мА})}=3.70...4.10\text{ В}; I_{ZT}<10\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K
8CA	BC848A	SAMS	nprn	$V_{CE0}=30\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=310\text{ мВт}; h_{21}>110...220; f_T>300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
8CA	BC848A	FAIR	nprn	$V_{CE0}=30\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=310\text{ мВт}; h_{21}>110...220; f_T>300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
8CB	BC848B	SAMS	nprn	$V_{CE0}=30\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=310\text{ мВт}; h_{21}>200...450; f_T>300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
8CB	BC848B	FAIR	npn	$V_{CE0} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 310$ мВт; $h_{21} > 200...450$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	B+E+C
8CC	BC848C	SAMS	npn	$V_{CE0} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 310$ мВт; $h_{21} > 420...800$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	B+E+C
8CC	BC848C	FAIR	npn	$V_{CE0} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 310$ мВт; $h_{21} > 420...800$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	B+E+C
8D	2DC4617Q	DIODS	npn	$V_{CE0} > 60$ В; $I_C < 150$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 120...270$; $f_T > 180$ МГц	SOT523	B+E+C
8D	DTC114YET1	MOT	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 68$; $f_T > 250$ МГц; $R_T/R_2 > 10/47$ кОм	SOT416, SC75A	B+E+C
8D	MMBZ5229B	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} > 20$ мА): 4.08...4.52 В; $I_R < 5$ мА	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8D	MMBZ5229BLT1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} > 20$ мА): 4.08...4.52 В; $I_R < 5$ мА	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8D	MUN2214T1	ON	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 230$ мВт; $h_{21} > 80$; 10 кОм/47 кОм	SOT346, SC59	B+E+C
8D	MUN5214T1	ON	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 200$ мВт; $h_{21} > 80$; 10 кОм/47 кОм	SOT323, SC70	B+E+C
8D	TMPZ5229	ALLEG	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} > 20$ мА): 4.08...4.52 В; $I_{(V_R = 1.0$ В)} < 5.0 мА; $Z_{T1}(I_{Z1} > 20$ мА) < 22 Ом	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8DA	BC849A	SAMS	npn	$V_{CE0} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 310$ мВт; $h_{21} > 110...220$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	B+E+C
8DA	BC849A	FAIR	npn	$V_{CE0} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 310$ мВт; $h_{21} > 110...220$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	B+E+C
8DB	BC849B	FAIR	npn	$V_{CE0} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 200...450$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	B+E+C
8DC	BC849C	FAIR	npn	$V_{CE0} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 420...800$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	B+E+C
8E	2DC4617R	DIODS	npn	$V_{CE0} > 60$ В; $I_C < 150$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 180...390$; $f_T > 180$ МГц	SOT523	B+E+C
8E	DTC114TET1	MOT	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 100...600$; $f_T > 250$ МГц; $R_T > 10$ кОм	SOT416, SC75A	B+E+C
8E	MMBZ5230B	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} > 20$ мА): 4.46...4.94 В; $I_R < 5$ мА	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8E	MMBZ5230BLT1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} > 20$ мА): 4.46...4.94 В; $I_R < 5$ мА	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8E	MUN2215T1	ON	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 230$ мВт; $h_{21} > 160$; $R_T > 10$ кОм	SOT346, SC59	B+E+C
8E	MUN5215T1	ON	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 200$ мВт; $h_{21} > 160$; $R_T > 10$ кОм	SOT323, SC70	B+E+C
8E	FMMTA92R	ZETEX	pnnp	$V_{CE0} > 300$ В; $I_C < 200$ мА; $P_D > 330$ мВт; $h_{21} > 25$; $f_T > 50$ МГц	SOT23, SOD23	E+B+C
8EA	BC850A	FAIR	npn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 310$ мВт; $h_{21} > 110...220$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	B+E+C
8EB	BC850B	FAIR	npn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 330$ мВт; $h_{21} > 200...450$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	B+E+C
8EC	BC850C	FAIR	npn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 330$ мВт; $h_{21} > 420...800$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	B+E+C
8F	2DC4617S	DIODS	npn	$V_{CE0} > 60$ В; $I_C < 150$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 270...560$; $f_T > 180$ МГц	SOT523	B+E+C
8F	DTC143TET1	MOT	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 100...600$; $f_T > 250$ МГц; $R_T > 4.7$ кОм	SOT416, SC75A	B+E+C
8F	MMBZ5231B	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} > 20$ мА): 4.84...5.36 В; $I_R < 5$ мА	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8F	MMBZ5231BLT1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} > 20$ мА): 4.84...5.36 В; $I_R < 5$ мА	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8F	MUN2216T1	ON	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 230$ мВт; $h_{21} > 160$; $R_T > 4.7$ кОм	SOT346, SC59	B+E+C
8F	MUN5216T1	ON	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 200$ мВт; $h_{21} > 160$; $R_T > 4.7$ кОм	SOT323, SC70	B+E+C
8G	FMMZ5232	ZETEX	dz	$V_Z > 5.6$ В; $Z_{T1}(I_Z > 20$ мА): 11 Ом	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8G	MMBZ5232B	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} > 20$ мА): 5.32...5.88 В; $I_R < 5$ мА	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8G	MMBZ5232BLT1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} > 20$ мА): 5.32...5.88 В; $I_R < 5$ мА	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8G	MUN2230T1	ON	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 230$ мВт; $h_{21} > 3$; 1 кОм/1 кОм	SOT346, SC59	B+E+C
8G	MUN5230T1	ON	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 200$ мВт; $h_{21} > 3$; 1 кОм/1 кОм	SOT323, SC70	B+E+C
8H	DTC123EET1	MOT	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 20$; $f_T > 250$ МГц; $R_T/R_2 > 2.2/2.2$ кОм	SOT416, SC75A	B+E+C
8H	FMMZ5233	ZETEX	dz	$V_Z > 6$ В; $Z_{T1}(I_Z > 20$ мА): 7 Ом	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8H	MMBZ5233B	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} > 20$ мА): 5.70...6.30 В; $I_R < 5$ мА	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8H	MMBZ5233BLT1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} > 20$ мА): 5.70...6.30 В; $I_R < 5$ мА	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8H	MUN2231T1	ON	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 230$ мВт; $h_{21} > 8$; 2.2 кОм/2.2 кОм	SOT346, SC59	B+E+C
8H	MUN5231T1	ON	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 200$ мВт; $h_{21} > 8$; 2.2 кОм/2.2 кОм	SOT323, SC70	B+E+C
8J	DTC143EET1	MOT	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 20$; $f_T > 250$ МГц; $R_T/R_2 > 4.7/4.7$ кОм	SOT416, SC75A	B+E+C
8J	FMMZ5234	ZETEX	dz	$V_Z > 6.2$ В; $Z_{T1}(I_Z > 20$ мА): 7 Ом	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8J	MMBZ5234B	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} > 20$ мА): 5.89...6.51 В; $I_R < 5$ мА	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8J	MMBZ5234BLT1	ON	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} > 20$ мА): 5.89...6.51 В; $I_R < 5$ мА	SOT23, SOD23	A+n.c.+K
8J	MUN2232T1	ON	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 230$ мВт; $h_{21} > 15$; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT346, SC59	B+E+C
8J	MUN5232T1	ON	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 200$ мВт; $h_{21} > 15$; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT323, SC70	B+E+C
8K	DTC143ZET1	MOT	Dnnpn	$V_{CE0} > 50$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D > 150$ мВт; $h_{21} > 80$; $f_T > 250$ МГц; $R_T/R_2 > 4.7/4.7$ кОм	SOT416, SC75A	B+E+C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
8K	FMZ5235	ZETEX	dz	$V_2 = 6.8 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 20 \text{ мА}) = 5 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8K	MMBZ5235B	VISH	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 6.46...7.14 \text{ В}; I_3 < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8K	MMBZ5235BLT1	ON	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 6.46...7.14 \text{ В}; I_3 < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8K	MUN223T1	ON	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 230 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
8K	MUN523T1	ON	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
8L	DTC124KE1	MOT	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 68; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 22/47 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
8L	FMZ5236	ZETEX	dz	$V_2 = 7.5 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 20 \text{ мА}) = 6 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8L	MMBZ5236B	VISH	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 7.12...7.88 \text{ В}; I_3 < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8L	MMBZ5236BLT1	ON	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 7.12...7.88 \text{ В}; I_3 < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8L	MUN2234T1	ON	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 230 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 22 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
8L	MUN5234T1	ON	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 22 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
8M	DTC123JET1	MOT	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 80; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 2.2/47 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
8M	FMZ5237	ZETEX	dz	$V_2 = 8.2 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 20 \text{ мА}) = 8 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8M	MMBZ5237B	VISH	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 7.79...8.61 \text{ В}; I_3 < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8M	MMBZ5237BLT1	ON	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 7.79...8.61 \text{ В}; I_3 < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8M	MUN5235T1	ON	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 2.2 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
8N	DTC115EET1	MOT	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_{C(MIN)} = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 82; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 100/100 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
8N	FMZ5238	ZETEX	dz	$V_2 = 8.7 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 20 \text{ мА}) = 8 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8N	MMBZ5238B	VISH	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 8.26...9.14 \text{ В}; I_3 < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8N	MMBZ5238BLT1	ON	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 8.26...9.14 \text{ В}; I_3 < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8N	MUN2236T1	ON	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 230 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 100 \text{ кОм}/100 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
8N	MUN5236T1	ON	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 100 \text{ кОм}/100 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
8P	DTC144WET1	MOT	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_{C(MIN)} = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 56; f_T > 250 \text{ МГц}; R_1/R_2 = 47/22 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
8P	FMZ5239	ZETEX	dz	$V_2 = 9.1 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 20 \text{ мА}) = 10 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8P	MMBZ5239B	VISH	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 8.65...9.56 \text{ В}; I_3 < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8P	MMBZ5239BLT1	ON	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 8.65...9.56 \text{ В}; I_3 < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8P	MUN2237T1	ON	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 230 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 41 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
8P	MUN5237T1	ON	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 47 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
8Q	FMZ5240	ZETEX	dz	$V_2 = 10 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 20 \text{ мА}) = 17 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8Q	MMBZ5240B	VISH	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 9.5...10.5 \text{ В}; I_3 < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8Q	MMBZ5240BLT1	ON	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 9.5...10.5 \text{ В}; I_3 < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8R	FMZ5241	ZETEX	dz	$V_2 = 11 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 20 \text{ мА}) = 22 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8R	MMBZ5241B	VISH	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 10.4...11.55 \text{ В}; I_3 < 2 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8R	MMBZ5241BLT1	ON	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 10.4...11.55 \text{ В}; I_3 < 2 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8S	FMZ5242	ZETEX	dz	$V_2 = 12 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 20 \text{ мА}) = 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8S	MMBZ5242B	VISH	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 11.4...12.6 \text{ В}; I_3 < 1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8S	MMBZ5242BLT1	ON	dz	$V_2(I_{T1} = 20 \text{ мА}) = 11.4...12.6 \text{ В}; I_3 < 1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8T	FMZ5243	ZETEX	dz	$V_2 = 13 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 9.5 \text{ мА}) = 13 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8T	MMBZ5243B	VISH	dz	$V_2(I_{T1} = 9.5 \text{ мА}) = 12.35...13.65 \text{ В}; I_3 < 0.5 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8T	MMBZ5243BLT1	ON	dz	$V_2(I_{T1} = 9.5 \text{ мА}) = 12.35...13.65 \text{ В}; I_3 < 0.5 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8T	MUN2240T1	ON	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 230 \text{ мВт}; h_{21} > 160; R_1, 47 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
8U	FMZ5244	ZETEX	dz	$V_2 = 14 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 9 \text{ мА}) = 15 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8U	MMBZ5244B	VISH	dz	$V_2(I_{T1} = 8.5 \text{ мА}) = 13.30...14.70 \text{ В}; I_3 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8U	MMBZ5244BLT1	ON	dz	$V_2(I_{T1} = 8.5 \text{ мА}) = 13.30...14.70 \text{ В}; I_3 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8U	MUN2241T1	ON	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 230 \text{ мВт}; h_{21} > 160; R_1, 100 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
8V	FMZ5245	ZETEX	dz	$V_2 = 15 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 8.5 \text{ мА}) = 16 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8V	MMBZ5245B	VISH	dz	$V_2(I_{T1} = 8.5 \text{ мА}) = 14.25...15.75 \text{ В}; I_3 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8V	MMBZ5245BLT1	ON	dz	$V_2(I_{T1} = 8.5 \text{ мА}) = 14.25...15.75 \text{ В}; I_3 < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8V2	PZM8.2NB	PHIL	dz	$V_2(I_{T1} = 5 \text{ мА}) = 7.76...8.64 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ мА}) < 10 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A-n.c.-K



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
8W	FMMZ5246	ZETEX	dz	$V_{21} = 16$ В; $Z_{T1}(I_2 = 7.8 \text{ mA}) = 17 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8W	MMBZ5246B	VISH	dz	$V_{21}(I_{21} = 7.8 \text{ mA}) = 15.2...16.8 \text{ В}$; $I_{B3} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8W	MMBZ5246BLT1	ON	dz	$V_{21}(I_{21} = 7.8 \text{ mA}) = 15.2...16.8 \text{ В}$; $I_{B3} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8X	FMMZ5247	ZETEX	dz	$V_{21} = 17$ В; $Z_{T1}(I_2 = 7.4 \text{ mA}) = 19 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8X	MMBZ5247B	VISH	dz	$V_{21}(I_{21} = 7.0 \text{ mA}) = 16.15...17.85 \text{ В}$; $I_{B3} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8X	MMBZ5247BLT1	ON	dz	$V_{21}(I_{21} = 7.0 \text{ mA}) = 16.15...17.85 \text{ В}$; $I_{B3} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8Y	FMMZ5248	ZETEX	dz	$V_{21} = 18$ В; $Z_{T1}(I_2 = 7 \text{ mA}) = 21 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8Y	MMBZ5248B	VISH	dz	$V_{21}(I_{21} = 7.0 \text{ mA}) = 17.1...18.9 \text{ В}$; $I_{B3} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8Y	MMBZ5248BLT1	ON	dz	$V_{21}(I_{21} = 7.0 \text{ mA}) = 17.1...18.9 \text{ В}$; $I_{B3} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8Z	FMMZ5249	ZETEX	dz	$V_{21} = 19$ В; $Z_{T1}(I_2 = 6.6 \text{ mA}) = 23 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8Z	MMBZ5249B	VISH	dz	$V_{21}(I_{21} = 6.2 \text{ mA}) = 18.05...19.95 \text{ В}$; $I_{B3} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8Z	MMBZ5249BLT1	ON	dz	$V_{21}(I_{21} = 6.2 \text{ mA}) = 18.05...19.95 \text{ В}$; $I_{B3} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
8Z	TMPZ5249	ALLEG	dz	$V_{21}(I_{21} = 6.6 \text{ mA}) = 18.1...20.0 \text{ В}$; $I_1(V_{21} = 14.0 \text{ В}) < 0.1 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{21} = 6.6 \text{ mA}) < 23 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
9.1X	OC2C9.1	TOSH	dz	$V_{21}(I_{21} = 5 \text{ mA}) = 8.50...9.60 \text{ В}$; $I_1(V_{21} = 7.0 \text{ В}) < 0.5 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{21} = 0.5 \text{ mA}) < 120 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
91A	FMMT591A	ZETEX	pnnp	$V_{CB0} = 40 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 500 \text{ мВт}$; $h_{21} = 300...800$; $f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
93	DTA143TE	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 4.7 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
93	DTA143TKA	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 4.7 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
93	DTA143TUA	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 4.7 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
94	DTA114TE	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 10 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
94	DTA114TKA	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 10 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
94	DTA114TUA	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 10 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
94	DTC114TE1	MOT	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} > 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 10 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
95	DTA124TE	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 22 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
95	DTA124TKA	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 22 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
95	DTA124TUA	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 22 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
95	DTA124TUA	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 22 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
96	DTA144TCA	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 47 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	B-E-C
96	DTA144TE	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 47 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
96	DTA144TKA	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 47 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
96	DTA144TUA	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 47 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
99	DTA115TE	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 100 \text{ кОм}$	SOT416, SC75A	B-E-C
99	DTA115TKA	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 100 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
99	DTA115TUA	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 100 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
9A	DTA125TKA	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 200 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
9A	DTA125TUA	ROHM	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...600$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_1 = 200 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
9A	FMMT2369AR	ZETEX	pnnp	$V_{CB0} = 40 \text{ В}$; $I_{C1} = 200 \text{ mA}$; $P_D = 330 \text{ мВт}$; $h_{21} = 40...120$	SOT23, SOD23	B-E-C
9A1	MMBZ9V1AL	ON	dz-2	$V_{21}(I_{21} = 1 \text{ mA}) = 8.65...9.56 \text{ В}$; $V_{21}(I_2 = 10 \text{ mA}) < 0.9 \text{ В}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
9A1	PZM9.1NB2A	PHIL	dz-2	$V_{21}(I_{21} = 5 \text{ mA}) = 8.85...9.23 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{21} = 5 \text{ mA}) < 10 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	K1-K2-A1, A2
9AA	BC856A	SAMS	pnnp	$V_{CB0} = 80 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 310 \text{ мВт}$; $h_{21} = 110...220$; $f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
9AB	BC856B	SAMS	pnnp	$V_{CB0} = 80 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 310 \text{ мВт}$; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
9AC	BC856C	SAMS	pnnp	$V_{CB0} = 80 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 310 \text{ мВт}$; $h_{21} = 420...800$; $f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
9BA	BC857A	SAMS	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 310 \text{ мВт}$; $h_{21} = 110...220$; $f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
9BB	BC857B	SAMS	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 310 \text{ мВт}$; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
9BC	BC857C	SAMS	pnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}$; $I_{C1} = 100 \text{ mA}$; $P_D = 310 \text{ мВт}$; $h_{21} = 420...800$; $f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
9CA	BC858A	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 30 В; I_C < 100 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} < 110...220; f_T > 150 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9CB	BC858B	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 30 В; I_C < 100 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} < 200...450; f_T > 150 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9CC	BC858C	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 30 В; I_C < 100 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} < 420...800; f_T > 150 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9DA	BC859A	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 30 В; I_C < 100 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} < 110...220; f_T > 150 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9DB	BC859B	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 30 В; I_C < 100 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} < 200...450; f_T > 150 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9DC	BC859C	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 30 В; I_C < 100 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} < 420...800; f_T > 150 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9EA	BC860A	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} < 110...220; f_T > 150 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9EB	BC860B	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} < 200...450; f_T > 150 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9EC	BC860C	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} < 420...800; f_T > 150 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9FA	BC807-16	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 50 В; I_C < 800 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} < 100...250; f_T > 100 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9FB	BC80725	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 50 В; I_C < 800 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} < 160...400; f_T > 100 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9FC	BC807-40	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 50 В; I_C < 800 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} < 250...630; f_T > 100 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9GA	BC808-16	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 30 В; I_C < 800 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} < 100...250; f_T > 100 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9GB	BC808-25	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 30 В; I_C < 800 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} < 160...400; f_T > 100 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9GC	BC808-40	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 30 В; I_C < 800 мА; P_D < 310 мВт; h_{21} < 250...630; f_T > 100 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9P	BCX70HR	ZETEX	pnp	$V_{CEB} > 45 В; I_C < 200 мА; P_D < 330 мВт; h_{21} < 180...310; f_T > 250 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
9R	FMMT2369R	ZETEX	pnp	$V_{CEB} > 40 В; I_C < 200 мА; P_D < 330 мВт; h_{21} < 40...120$	SOT23,SOD23	B-E-C
9V1	PZM9.1NB	PHIL	dz	$V_{I(ZT)} < 5 мА > 8.56...9.55 В; Z_{T(I-ZT)} < 5 мА > 10 Ом$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
A	IRLML2402	IR	nMOS	HEXFET; $V_{GS} < 20 В; I_D < 0.9 А; P_D < 540 мВт; R_{DS(on)} < 0.35 Ом$	SOT23,SOD23	G-S-D
A	MRF947T1	MOT	pnp	$V_{CEB} > 20 В; I_C < 50 мА; P_D < 188 мВт; h_{21} > 50; f_T < 8 ГГц$	SOT323,SC70	B-E-C
A0	HSMS2800	HP	shd	$V_{BR} > 70 В; V_{F(I_F = 15 мА)} < 1.0 В; I_n(V_{R1} = 50 В) < 200 нА; C_0 < 2.0 пФ$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A0	HSMS280B	HP	shd	$V_{BR} > 70 В; V_{F(I_F = 15 мА)} < 1.0 В; I_n(V_{R1} = 50 В) < 200 нА; C_0 < 2.0 пФ$	SOT323,SC70	A-n.c.-K
A03	SST203	CALOG	nFET	$V_{GS} < 40 В; P_D < 350 мВт; I_{DSS} < 4...20 мА; g_m < 1.5 мСм$	SOT23,SOD23	D-S-G
A1	BAW56	ALLEG	di-2	$I_F < 70 мА; V_{BR} > 70 В; V_{F(I_F = 50 мА)} < 1.1 В; I_n < 2500 нА; t_{RR} < 6.0 нс; C_0 < 2.0 пФ$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
A1	BAW56	VISH	di-2	$V_F < 70 В; I_F < 300 мА; V_{F(I_F = 150 мА)} < 1.25 В; I_n < 5.0 мкА; C_0 < 4.0 пФ; t_{RR} < 6 нс$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
A1	BAW56	ZETEX	di-2	$V_F < 70 В; I_F < 100 мА; V_{F(I_F = 50 мА)} < 1.1 В; I_n < 2.5 мкА; C_0 < 2.0 пФ; t_{RR} < 6 нс$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
A1	BAW56	FAIR	di-2	$V_F < 85 В; I_F < 200 мА; V_{F(I_F = 50 мА)} < 1 В; I_n < 2.5 мкА; C_0 < 2.0 пФ; t_{RR} < 6 нс$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
A1	BAW56W	PHIL	di-2	$V_F < 75 В; I_F < 150 мА; V_{F(I_F = 50 мА)} < 1.0 В; C_0 < 2 пФ; t_{RR} < 4 нс$	SOT323,SC70	K1-K2-A2,A1
A1	BAW56WT1	ON	di-2	$V_F < 70 В; I_F < 200 мА; V_{F(I_F = 150 мА)} < 1.25 В; I_n < 2 мкА; t_{RR} < 4 нс$	SOT323,SC70	K1-K2-A1,A2
A1	HSMS2801	HP	shd	$V_{BR} > 70 В; V_{F(I_F = 15 мА)} < 1.0 В; I_n(V_{R1} = 50 В) < 200 нА; C_0 < 2.0 пФ$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A11	MMBD1501A	NS	dl	$V_F < 180 В; I_F < 600 мА; V_{F(I_F = 200 мА)} < 1.1 В; C_0 < 4 пФ$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A11	MMBD1501A	FAIR	dl	$V_F < 200 В; I_F < 200 мА; V_{F(I_F = 200 мА)} < 1.1 В; C_0 < 4 пФ$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A13	MMBD1503A	NS	di-2	$V_F < 180 В; I_F < 600 мА; V_{F(I_F = 200 мА)} < 1.1 В; C_0 < 4 пФ$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
A13	MMBD1503A	FAIR	di-2	$V_F < 200 В; I_F < 200 мА; V_{F(I_F = 200 мА)} < 1.1 В; C_0 < 4 пФ$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
A14	MMBD1504A	NS	di-2	$V_F < 180 В; I_F < 600 мА; V_{F(I_F = 200 мА)} < 1.1 В; C_0 < 4 пФ$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
A14	MMBD1504A	FAIR	di-2	$V_F < 200 В; I_F < 200 мА; V_{F(I_F = 200 мА)} < 1.1 В; C_0 < 4 пФ$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
A15	MMBD1505A	NS	di-2	$V_F < 180 В; I_F < 600 мА; V_{F(I_F = 200 мА)} < 1.1 В; C_0 < 4 пФ$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
A15	MMBD1505A	FAIR	di-2	$V_F < 200 В; I_F < 200 мА; V_{F(I_F = 200 мА)} < 1.1 В; C_0 < 4 пФ$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
A16	ZC934A	ZETEX	var	$V_F < 12 В; C_0(V_F = 2.5 В) < 47.25...57.75 пФ; C_{1B}/C_{1G} < 3.8; Q > 80$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A17	ZC933A	ZETEX	var	$V_F < 12 В; C_0(V_F = 2.5 В) < 20.25...24.75 пФ; C_{1B}/C_{1G} < 3.5; Q > 150$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A1s	BAW56	INF	di-2	$V_F < 80 В; I_F < 200 мА; V_{F(I_F = 150 мА)} < 1.25 В; C_0 < 2.0 пФ; t_{RR} < 4 нс$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
A1s	BAW56T	INF	di-2	$V_F < 80 В; I_F < 200 мА; V_{F(I_F = 150 мА)} < 1.25 В; C_0 < 2.0 пФ; t_{RR} < 4 нс$	SOT416,SC75A	K1-K2-A1,A2
A1s	BAW56W	INF	di-2	$V_F < 80 В; I_F < 200 мА; V_{F(I_F = 150 мА)} < 1.25 В; C_0 < 2.0 пФ; t_{RR} < 4 нс$	SOT323,SC70	K1-K2-A1,A2
A1s	BAW56T	PHIL	di-2	$V_F < 75 В; I_F < 150 мА; V_{F(I_F = 150 мА)} < 1.25 В; t_{RR} < 4 нс$	SOT416,SC75A	K1-K2-A1,A2
A1X	MBAW56	MOT	di-2	$V_F < 70 В; I_F < 300 мА; V_{F(I_F = 150 мА)} < 1.25 В; I_n < 5.0 мкА; C_0 < 4.0 пФ; t_{RR} < 6 нс$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
A2	BAS16T	DIODS	dl	$V_F < 85 В; I_F < 155 мА; V_{F(I_F = 150 мА)} < 1.25 В; I_n < 2 мкА; t_{RR} < 4 нс$	SOT523	A-n.c.-K
A2	BAT18	SIEM	cpin	$V_F < 35 В; I_F < 100 мА; V_{F(I_F = 100 мА)} < 1.2 В; I_n < 0.02 мкА; C_0 < 1.0 пФ$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A2	BAT18	PHIL	dlv	$V_F < 35 В; I_F < 100 мА; P_D < 0.7 Ом; C_0 < 1.0 пФ$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A2	FMMD2836	ZETEX	fid-2	$V_F < 75 В; I_F < 100 мА; V_{F(I_F = 50 мА)} < 1.0 В; I_n < 0.1 мкА; C_0 < 4.0 пФ; t_{RR} < 6 нс$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
A2	HSMS2802	HP	shd-2	$V_{BR} > 70 В; V_{F(I_F = 15 mA)} < 1.0 В; I_{B(I_B = 50 В)} < 200 нА; C_D < 2.0 пФ$	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
A2	HSMS280C	HP	shd-2	$V_{BR} > 70 В; V_{F(I_F = 15 mA)} < 1.0 В; I_{B(I_B = 50 В)} < 200 нА; C_D < 2.0 пФ$	SOT23,SC70	A1•K2•K1,A2
A2	MMBD1448	VISH	di	$V_{F_1} > 75 В; I_C < 300 мА; V_{F_2(I_F = 10 mA)} < 1.0 В; I_{B_1} < 5.0 мкА; C_D < 4 нФ; t_{BR} < 6 нс$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A2s	BAT18	INF	cpin	$V_{F_1} < 35 В; I_C < 100 мА; V_{F_2(I_F = 100 mA)} < 1.2 В; I_{B_1} < 0.02 мкА; C_D < 1.0 пФ$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A2x	MMBD2836LT1	MOT	di-2	$V_{F_1} > 75 В; I_C < 100 мА; V_{F_2(I_F = 50 mA)} < 1 В; C_D < 4 нФ; t_{BR} < 4 нс$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A3	1PS300	PHIL	fd-2	$V_{F_1} > 80 В; I_C < 200 мА; V_{F_2(I_F = 50 mA)} < 1.0 В; C_D < 2.0 пФ; t_{BR} < 4 нс$	SOT23,SC70	K1•K2•A1,A2
A3	1SS181	TOSH	di-2	$V_{F_1} < 80 В; I_C < 100 мА; V_{F_2(I_F = 100 mA)} < 1.2 В; I_{B_1} < 0.5 мкА; t_{BR} < 4 нс$	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
A3	1SS300	TOSH	di-2	$V_{F_1} < 80 В; I_C < 100 мА; V_{F_2(I_F = 100 mA)} < 1.2 В; t_{BR} < 4 нс$	SOT23,SC70	K1•K2•A1,A2
A3	1SS360	TOSH	di-2	$V_{F_1} < 80 В; I_C < 100 мА; V_{F_2(I_F = 100 mA)} < 1.2 В; I_{B_1} < 0.5 мкА; t_{BR} < 4 нс$	SOT416,SC75A	K1•K2•A1,A2
A3	1SS360F	TOSH	di-2	$V_{F_1} < 80 В; I_C < 100 мА; V_{F_2(I_F = 100 mA)} < 1.2 В; I_{B_1} < 0.5 мкА; t_{BR} < 4 нс$	SOT490,SC89	K1•K2•A1,A2
A3	HSMS2803	HP	shd-2	$V_{BR} > 70 В; V_{F(I_F = 15 mA)} < 1.0 В; I_{B(I_B = 50 В)} < 200 нА; C_D < 2.0 пФ$	SOT23,SOD23	A1•n.c.•K
A3	HSMS280E	HP	shd-2	$V_{BR} > 70 В; V_{F(I_F = 15 mA)} < 1.0 В; I_{B(I_B = 50 В)} < 200 нА; C_D < 2.0 пФ$	SOT23,SC70	K1•K2•A1,A2
A3	KDS120	KEC	di-2	$V_{F_1} > 80 В; I_C < 100 мА; I_{B_1} < 0.5 мкА; C_D < 2.2 пФ$	SOT23,SC70	K1•K2•A1,A2
A3	MMBD1005LT1	MOT	di-2	$V_{F_1} > 30 В; I_C < 200 мА; V_{F_2(I_F = 10 mA)} < 0.95 В$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A3	MMBD4448	VISH	fid	$V_{F_1} > 75 В; I_C < 500 мА; V_{F_2(I_F = 100 mA)} < 1.0 В; I_{B_1} < 5.0 мкА; C_D < 4 нФ; t_{BR} < 4 нс$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
A3p	BAT17	PHIL	shd	$V_{F_1} < 4 В; I_C < 30 мА; V_{F_2(I_F = 1 mA)} < 450 мВ; C_D < 1 пФ$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K
A3p	BAT17	PHIL	shd	$V_{F_1} < 4 В; I_C < 30 мА; V_{F_2(I_F = 1 mA)} < 450 мВ; C_D < 1 пФ$	SOT23,SOD23	A1•n.c.~K
A3t	BAT17	PHIL	shd	$V_{F_1} < 4 В; I_C < 30 мА; V_{F_2(I_F = 1 mA)} < 450 мВ; C_D < 1 пФ$	SOT23,SOD23	A1•n.c.~K
A3X	MMBD2835LT1	MOT	di-2	$V_{F_1} < 35 В; I_C < 100 мА; V_{F_2(I_F = 50 mA)} < 1 В; C_D < 4 нФ; t_{BR} < 4 нс$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A4	BAV70	ALLEG	di-2	$I_C < 100 мА; V_{BR} > 70 В; V_{F_1(I_F = 10 mA)} < 0.86 В; I_{B_1} < 5000 нА; t_{BR} < 6.0 нс; C_D < 1.5 пФ$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70	VISH	di-2	$V_{F_1} < 70 В; I_C < 300 мА; V_{F_2(I_F = 150 mA)} < 1.25 В; I_{B_1} < 5.0 мкА; C_D < 4 пФ; t_{BR} < 6 нс$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70	ZETEX	di-2	$V_{F_1} > 70 В; I_C < 100 мА; V_{F_2(I_F = 50 mA)} < 1.1 В; I_{B_1} < 5.0 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{BR} < 6 нс$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70	MCC	di-2	$V_{F_1} > 75 В; I_C < 150 мА; V_{F_2(I_F = 10 mA)} < 0.855 В; C_D < 2 пФ; t_{BR} < 4 нс$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70	Nat	di-2	$V_{F_1} < 70 В; I_C < 200 мА; V_{F_2(I_F = 10 mA)} < 0.855 В; C_D < 1.5 пФ; t_{BR} < 6 нс$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70	ZOWIE	di-2	$V_{F_1} > 70 В; I_C < 200 мА; V_{F_2(I_F = 10 mA)} < 0.855 В; C_D < 1.5 пФ; t_{BR} < 6 нс$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70	PANJIT	di-2	$V_{F_1} > 75 В; I_C < 150 мА; V_{F_2(I_F = 10 mA)} < 1 В; C_D < 4 пФ; t_{BR} < 4 нс$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70TT1	ON	di-2	$V_{F_1} < 70 В; I_C < 200 мА; V_{F_2(I_F = 50 mA)} < 1 В; C_D < 1.5 пФ; t_{BR} < 6 нс$	SOT416,SC75A	A1•A2•K1,K2
A4	BAV70W	PHIL	di-2	$V_{F_1} > 70 В; I_C < 175 мА; V_{F_2(I_F = 50 mA)} < 1.0 В; C_D < 1.5 пФ; t_{BR} < 4 нс$	SOT23,SC70	A1•A2•K1,K2
A4	HSMS2804	HP	shd-2	$V_{BR} > 70 В; V_{F(I_F = 15 mA)} < 1.0 В; I_{B(I_B = 50 В)} < 200 нА; C_D < 2.0 пФ$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4	HSMS280F	HP	shd-2	$V_{BR} > 70 В; V_{F(I_F = 15 mA)} < 1.0 В; I_{B(I_B = 50 В)} < 200 нА; C_D < 2.0 пФ$	SOT23,SC70	A1•A2•K1,K2
A4p	BAV70	PHIL	di-2	$V_{F_1} > 70 В; I_C < 215 мА; V_{F_2(I_F = 50 mA)} < 1.0 В; C_D < 1.5 пФ; t_{BR} < 4 нс$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4s	BAV70	INF	di-2	$V_{F_1} < 80 В; I_C < 200 мА; V_{F_2(I_F = 50 mA)} < 1 В; I_{B_1}(V_{F_1} = 70 В) < 0.15 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{BR} < 4 нс$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A4s	BAV70F	INF	di-2	$V_{F_1} < 80 В; I_C < 200 мА; V_{F_2(I_F = 50 mA)} < 1 В; I_{B_1}(V_{F_1} = 70 В) < 0.15 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{BR} < 4 нс$	TSFP-3,VESM	A1•A2•K1,K2
A4s	BAV70T	INF	di-2	$V_{F_1} < 80 В; I_C < 200 мА; V_{F_2(I_F = 50 mA)} < 1 В; I_{B_1}(V_{F_1} = 70 В) < 0.15 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{BR} < 4 нс$	SOT416,SC75A	A1•A2•K1,K2
A4s	BAV70W	INF	di-2	$V_{F_1} < 80 В; I_C < 200 мА; V_{F_2(I_F = 50 mA)} < 1 В; I_{B_1}(V_{F_1} = 70 В) < 0.15 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{BR} < 4 нс$	SOT23,SC70	A1•A2•K1,K2
A4X	MBAV70	MOT	di-2	$V_{F_1} > 70 В; I_C < 300 мА; V_{F_2(I_F = 150 mA)} < 1.25 В; I_{B_1} < 5.0 мкА; C_D < 4 пФ; t_{BR} < 6 нс$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A5	FMMD2837	ZETEX	fid-2	$V_{F_1} < 35 В; I_C < 100 мА; V_{F_2(I_F = 50 mA)} < 1.0 В; I_{B_1} < 0.1 мкА; C_D < 4.0 пФ; t_{BR} < 6 нс$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A5	MMBD2837LT1	MOT	di-2	$V_{F_1} < 30 В; I_C < 150 мА; V_{F_2(I_F = 50 mA)} < 1 В; C_D < 4 пФ; t_{BR} < 4 нс$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
A5p	BRY61	PHIL	pinpn	$V_{D_1} > 70 В; I_C < 175 мА; P_D < 250 мВт; I_{B_1} < 80 нс$	SOT23,SOD23	A•K•G
A5t	BRY61	PHIL	pinpn	$V_{D_1} > 70 В; I_C < 175 мА; P_D < 250 мВт; I_{B_1} < 80 нс$	SOT23,SOD23	A•K•G
A6	BAS16	ALLEG	di	$I_C < 600 мА; V_{BR} > 75 В; V_{F_1(I_F = 1 mA)} < 0.72 В; I_{B_1} < 1000 нА; t_{BR} < 6.0 нс; C_D < 2.0 пФ$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K
A6	BAS16	FAIR	di	$V_{F_1} < 85 В; I_C < 200 мА; V_{F_2(I_F = 150 mA)} < 1.25 В; I_{B_1} < 1.0 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{BR} < 6 нс$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K
A6	BAS16	DIOT	di	$V_{F_1} < 85 В; I_C < 200 мА; V_{F_2(I_F = 150 mA)} < 1.25 В; I_{B_1} < 1.0 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{BR} < 6 нс$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K
A6	BAS16	ZETEX	di	$V_{F_1} < 75 В; I_C < 250 мА; V_{F_2(I_F = 50 mA)} < 1.0 В; I_{B_1} < 1.0 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{BR} < 6 нс$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K

**SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3**

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
A6	BAS16	VISH	fid	$V_{R1} < 75 \text{ В}; I_{R1} < 500 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 1.0 \text{ мкА}; C_D < 4.0 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A6	BAS16	PANJIT	di	$V_{R1} < 75 \text{ В}; I_{R1} < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 10 \text{ мА}) < 0.855 \text{ В}; I_{R2} < 1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 6 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A6	BAS16T	PHIL	di	$V_{R1} < 75 \text{ В}; I_{R1} < 155 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 50 \text{ мкА}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	SOT416,SOT375A	A-n.c.-K
A6	BAS16TT1	ON	di	$V_{R1} < 75 \text{ В}; I_{R1} < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 1 \text{ мкА}; t_{\text{TRR}} < 6 \text{ нс}$	SOT416,SC75A	A-n.c.-K
A6	BAS16W	PANJIT	di	$V_{R1} < 75 \text{ В}; I_{R1} < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 10 \text{ мА}) < 0.855 \text{ В}; I_{R2} < 1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 6 \text{ нс}$	SOT323,SC70	A-n.c.-K
A6	BAS16W	PHIL	di	$V_{R1} < 75 \text{ В}; I_{R1} < 175 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 50 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	SOT323,SC70	A-n.c.-K
A6A	MMUN2111LT1	ON	Dpnp	$V_{\text{CBO}} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 246 \text{ мВт}; h_{21} > 35; 10 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
A6B	MMUN2112LT1	ON	Dpnp	$V_{\text{CBO}} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 246 \text{ мВт}; h_{21} > 60; 22 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
A6C	MMUN2113LT1	ON	Dpnp	$V_{\text{CBO}} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 246 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 47 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
A6D	MMUN2114LT1	ON	Dpnp	$V_{\text{CBO}} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 246 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 100 \text{ кОм}/100 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
A6E	MMUN2115LT1	ON	Dpnp	$V_{\text{CBO}} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 246 \text{ мВт}; h_{21} > 160; R_1 < 10 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
A6F	MMUN2116LT1	ON	Dpnp	$V_{\text{CBO}} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 246 \text{ мВт}; h_{21} > 160; R_1 < 4.7 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
A6G	MMUN2130LT1	ON	Dpnp	$V_{\text{CBO}} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 246 \text{ мВт}; h_{21} > 3; 1 \text{ кОм}/1 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
A6H	MMUN2131LT1	ON	Dpnp	$V_{\text{CBO}} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 246 \text{ мВт}; h_{21} > 8; 2.2 \text{ кОм}/2.2 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
A6J	MMUN2132LT1	ON	Dpnp	$V_{\text{CBO}} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 246 \text{ мВт}; h_{21} > 15; 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
A6K	MMUN2133LT1	ON	Dpnp	$V_{\text{CBO}} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 246 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
A6L	MMUN2134LT1	ON	Dpnp	$V_{\text{CBO}} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 246 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 22 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
A6p	BAS16	PHIL	fd	$V_{R1} < 75 \text{ В}; I_{R1} < 215 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 50 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A6s	BAS16	SIEM	di	$V_{R1} < 75 \text{ В}; I_{R1} < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 50 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R2} < 1.0 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 6 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A6s	BAS16	INF	di	$V_{R1} < 80 \text{ В}; I_{R1} < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 50 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A6s	BAS16W	INF	di	$V_{R1} < 80 \text{ В}; I_{R1} < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 50 \text{ мкА}$	SOT323,SC70	A-n.c.-K
A7	BAV99	ALLEG	di-2	$I_{R1} < 70 \text{ мА}; V_{\text{BR}} > 70 \text{ В}; V_{F1}(I_{R1} = 50 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; I_{R2} < 2500 \text{ нА}; t_{\text{TRR}} < 6.0 \text{ нс}; C_D < 2.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
A7	BAV99	VISH	di-2	$V_{R1} < 70 \text{ В}; I_{R1} < 300 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 5.0 \text{ мкА}; C_D < 4.0 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 6 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
A7	BAV99	ZETEX	di-2	$V_{R1} < 70 \text{ В}; I_{R1} < 100 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 50 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; I_{R2} < 2.5 \text{ мкА}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 6 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
A7	BAV99	DIOT	di-2	$V_{R1} < 70 \text{ В}; I_{R1} < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 2 \text{ мкА}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
A7	BAV99	ZOWIE	di-2	$V_{R1} < 70 \text{ В}; I_{R1} < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 2 \text{ мкА}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
A7	BAV99	MCC	di-2	$V_{R1} < 75 \text{ В}; I_{R1} < 150 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 2.5 \text{ мкА}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
A7	BAV99	Nat	di-2	$V_{R1} < 70 \text{ В}; I_{R1} < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; t_{\text{TRR}} < 6 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
A7	BAV99	JGD	di-2	$V_{R1} < 75 \text{ В}; I_{R1} < 300 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 2 \text{ мкА}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
A7	BAV99W	DIOT	di-2	$V_{R1} < 70 \text{ В}; I_{R1} < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 2 \text{ мкА}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	SOT323,SC70	A1-K1,A2-K2
A7	BAV99W	PHIL	fd-2	$V_{R1} < 75 \text{ В}; I_{R1} < 150 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 50 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; C_D < 1.55 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	SOT323,SC70	A1-K2-K1,A2
A7	BAV99WT1	ON	di-2	$V_{R1} < 70 \text{ В}; I_{R1} < 215 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 2 \text{ мкА}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	SOT323,SC70	A1-K1,A2-K2
A7	DAN217U	ROHM	di-2	$V_{R1} < 80 \text{ В}; I_{R1} < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; V_{F1}(I_{R1} = 100 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}$	SOT323,SC70	A1-K2-K1,A2
A7p	BAV99	PHIL	di-2	$V_{R1} < 75 \text{ В}; I_{R1} < 215 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 50 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
A7s	BAV99	INF	di-2	$V_{R1} < 80 \text{ В}; I_{R1} < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 0.15 \text{ мкА}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
A7s	BAV99F	INF	di-2	$V_{R1} < 80 \text{ В}; I_{R1} < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 0.15 \text{ мкА}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	TSPF-3,VESM	A1-K2-K1,A2
A7s	BAV99T	INF	di-2	$V_{R1} < 80 \text{ В}; I_{R1} < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 0.15 \text{ мкА}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	SOT416,SC75A	A1-K2-K1,A2
A7s	BAV99W	INF	di-2	$V_{R1} < 80 \text{ В}; I_{R1} < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 0.15 \text{ мкА}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 4 \text{ нс}$	SOT323,SC70	A1-K2-K1,A2
A8	BAS19	ALLEG	d	$I_{R1} < 200 \text{ мА}; V_{\text{BR}} > 100 \text{ В}; V_{F1}(I_{R1} = 200 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 100 \text{ нА}; t_{\text{TRR}} < 50 \text{ нс}; C_D < 5.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A8	BAS19	PANJIT	di	$V_{R1} < 100 \text{ В}; I_{R1} < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R2} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 50 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A8	BAS19	JGD	di	$V_{R1} < 100 \text{ В}; I_{R1} < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R2} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 50 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
A8	BAS19	VISH	di	$V_{R1} < 100 \text{ В}; I_{R1} < 400 \text{ мА}; V_{F1}(I_{R1} = 200 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R2} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ нФ}; t_{\text{TRR}} < 50 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TSM VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
A8	BAS19	ZETEX	di	$V_B < 100 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F(I_C=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_C < 5.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 50 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
A8	BAS19W	PANJIT	di	$V_B < 100 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F(I_C=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_C < 2 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 50 \text{ нс}$	SOT23,SC70	A•n.c•K
A8	SI2308DS	VISH	nMOS	$V_{DS} = 60 \text{ В}; I_D = 1.6 \text{ А}; P_D = 800 \text{ мВт}; R_{\theta(\text{жел})} < 0.22 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	G•S•D
A80	BAS20	PANJIT	di	$V_B < 150 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F(I_C=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_C < 1.5 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 50 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
A80	BAS20W	PANJIT	di	$V_B < 150 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F(I_C=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_C < 1.5 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 50 \text{ нс}$	SOT23,SC70	A•n.c•K
A81	BAS20	JGD	di	$V_B < 150 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F(I_C=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_C < 1.5 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 50 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
A81	BAS20	VISH	di	$V_B < 150 \text{ В}; I_C < 400 \text{ мА}; V_{F(I_C=200 \text{ мА})} < 1.25 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_C < 5.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 50 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
A81	BAS20	ZETEX	di	$V_B < 150 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F(I_C=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_C < 5.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 50 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
A82	BAS21	ALLEG	di	$I_C < 200 \text{ мА}; V_{\text{BR}} > 200 \text{ В}; V_{F(I_C=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_S < 100 \text{ нА}; t_{\text{рег}} < 50 \text{ нс}; C_C < 5.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
A82	BAS21	PANJIT	di	$V_B < 200 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F(I_C=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_C < 1.5 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 50 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
A82	BAS21	VISH	di	$V_B < 200 \text{ В}; I_C < 400 \text{ мА}; V_{F(I_C=200 \text{ мА})} < 1.25 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_C < 5.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 50 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
A82	BAS21	ZETEX	di	$V_B < 200 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F(I_C=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_C < 5.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 50 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
A82	BAS21W	PANJIT	di	$V_B < 200 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F(I_C=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_C < 1.5 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 50 \text{ нс}$	SOT23,SC70	A•n.c•K
A82	CMPPD2003	CSI	di	$I_C < 250 \text{ мА}; V_B = 200 \text{ В}; V_{F(I_C=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_S < 100 \text{ нА}; t_{\text{рег}} < 50 \text{ нс}; C_C < 5.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
A8A	MMJUN2211LT1	ON	Dnnp	$V_{\text{CBO}} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 35; 10 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B•E•C
A8B	MMJUN2212LT1	ON	Dnnp	$V_{\text{CBO}} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 60; 22 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B•E•C
A8C	MMJUN2213LT1	ON	Dnnp	$V_{\text{CBO}} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 47 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B•E•C
A8D	MMJUN2214LT1	ON	Dnnp	$V_{\text{CBO}} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 100 \text{ кОм}/100 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B•E•C
A8E	MMJUN2215LT1	ON	Dnnp	$V_{\text{CBO}} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 160; R_1 = 10 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B•E•C
A8F	MMJUN2216LT1	ON	Dnnp	$V_{\text{CBO}} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 160; R_1 = 4.7 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B•E•C
A8G	MMJUN2230LT1	ON	Dnnp	$V_{\text{CBO}} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 3; 1 \text{ кОм}/1 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B•E•C
A8H	MMJUN2231LT1	ON	Dnnp	$V_{\text{CBO}} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 8; 2.2 \text{ кОм}/2.2 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B•E•C
A8J	MMJUN2232LT1	ON	Dnnp	$V_{\text{CBO}} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 15; 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B•E•C
A8K	MMJUN2233LT1	ON	Dnnp	$V_{\text{CBO}} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B•E•C
A8L	MMJUN2234LT1	ON	Dnnp	$V_{\text{CBO}} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 22 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B•E•C
A8R	MMJUN2238LT1	ON	Dnnp	$V_{\text{CBO}} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 160; R_1 = 2.2 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B•E•C
A8U	MMJUN2241LT1	ON	Dnnp	$V_{\text{CBO}} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 160; R_1 = 100 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B•E•C
A9	1SS294	TOSH	shd	$V_B > 40 \text{ В}; V_{F(I_C=100 \text{ мА})} < 0.6 \text{ В}; I_S(V_B=40 \text{ В}) < 5 \text{ мкА}; C_C < 25 \text{ пФ}$	SOT346,SC59	A•n.c•K
A9	1SS322	TOSH	shd	$V_B > 40 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; V_{F(I_C=100 \text{ мА})} < 0.6 \text{ В}; C_C < 18 \text{ пФ}$	SOT23,SC70	A•n.c•K
A9	FMMD2835	ZETEX	fid-2	$V_B < 35 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; V_{F(I_C=50 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_S < 0.1 \text{ мкА}; C_C < 4.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 6 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
A9	SI2309DS	VISH	pMOS	$V_{DS} = 60 \text{ В}; I_D = 0.85 \text{ А}; P_D = 800 \text{ мВт}; R_{\theta(\text{жел})} < 0.55 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	G•S•D
A91	BAS17	PHIL	dz	$V_B < 5 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{F(I_C=100 \text{ мА})} < 0.96 \text{ В}; I_S < 5 \text{ мкА}; C_C < 140 \text{ пФ}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
AA	BCW60A	ALLEG	nnpn	$V_{\text{CBO}} = 32 \text{ В}; I_{\text{CBO}} < 20 \text{ мА}; h_{21} = 120...220; V_{\text{CE(sat)}} < 0.35 \text{ В}; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
AA	BCW60A	CDIL	nnpn	$V_{\text{CBO}} = 32 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 120...220; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
AA	BCW60A	SAMS	nnpn	$V_{\text{CBO}} = 32 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 120...220; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
AA	BCW60A	ZETEX	nnpn	$V_{\text{CBO}} = 32 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 120...220; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
AAA	MAX6806XR46	MAX	vd	$V_{\text{TR}} = 4.6 \text{ В}; V_{\text{DD}} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{\text{CC}} < 80 \text{ мкА}$	SOT323,SC70	RST•GND•V _{CC}
AAA	MMBF4856LT1	MOT	nFET	$V_{DS} = 40 \text{ В}; I_{\text{DSS}} = 50 \text{ мА}; P_D = 225 \text{ мВт}$	SOT23,SOD23	D•S•G
AAAA	MAX809LUR	MAX	mrc	$V_{\text{TR}} = 4.63 \text{ В}; V_{\text{DD}} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{\text{CC}} < 100 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND•RST•V _{CC}
AAB	MAX6806XR26	MAX	vd	$V_{\text{TR}} = 2.6 \text{ В}; V_{\text{DD}} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{\text{CC}} < 80 \text{ мкА}$	SOT323,SC70	RST•GND•V _{CC}
AAC	MAX6806XR23	MAX	vd	$V_{\text{TR}} = 2.3 \text{ В}; V_{\text{DD}} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{\text{CC}} < 80 \text{ мкА}$	SOT323,SC70	RST•GND•V _{CC}
AAD	CMPPD4448	CSI	dih	$I_C < 250 \text{ мА}; V_B = 75 \text{ В}; V_{F(I_C=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_S < 25 \text{ нА}; t_{\text{рег}} < 4.0 \text{ нс}; C_C < 4.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
AAD	MAX6807XR46	MAX	vd	$V_{TR} = 4.6\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 80\text{ мкА}$	SOT323,SC70	RST·GND·V _{CC}
AAD	TMPD4448	ALLEG	d	$I_C < 600\text{ мА}; V_{BR} > 100\text{ В}; V_{I(f)} = 100\text{ мА} < 1.0\text{ В}; I_B < 25\text{ нА}; I_{RR} < 4.0\text{ нС}; C_0 < 4.0\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A·n.c.·K
AAE	MAX6807XR26	MAX	vd	$V_{TR} = 2.6\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 80\text{ мкА}$	SOT323,SC70	RST·GND·V _{CC}
AAF	MAX6808XR46	MAX	vd	$V_{TR} = 4.6\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 80\text{ мкА}$	SOT323,SC70	RST·GND·V _{CC}
AAG	MAX6808XR26	MAX	vd	$V_{TR} = 2.6\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 80\text{ мкА}$	SOT323,SC70	RST·GND·V _{CC}
AAG	MMBR951AL11	MOT	npn	$V_{CEB} = 20\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 322\text{ мВт}; h_{21} = 75...150; f_T = 8000\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B·E·C
AAN	MAX6326XR22	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.2\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AAJ	MAX6327XR22	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.2\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AAJ	MAX6328XR22	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.2\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AAN	MAX809LXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AAO	MAX809MXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AAP	BCW60A	PHIL	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 120...220; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B·E·C
AAP	MAX809TXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AAQ	2SD1757KQ	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 120...270; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT346,SC59	B·E·C
AAQ	MAX809SXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AAR	2SD1757KR	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 180...390; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT346,SC59	B·E·C
AAR	MAX809RXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AAR	TMPD4153	ALLEG	d	$I_C < 600\text{ мА}; V_{BR} > 75\text{ В}; V_{I(f)} = 1\text{ мА} < 0.67\text{ В}; I_B < 50\text{ нА}; I_{RR} < 4.0\text{ нС}; C_0 < 4.0\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A·n.c.·K
AAS	2SD1757KS	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 270...560; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT346,SC59	B·E·C
AAS	BCW60B	SIEM	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 120...220; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B·E·C
AAS	MAX809ZXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AAT	MAX810LXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AAU	MAX810MXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AAV	MAX810TXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AAW	MAX810RXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AAX	MAX810SXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AAZ	MAX810ZXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AAZ	MAX803LXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
AB	BCW60B	ALLEG	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_{CB} < 20\text{ нА}; h_{21} = 180...310; V_{CE(sat)} < 0.35\text{ В}; f_T > 125\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B·E·C
AB	BCW60B	CDIL	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 180...320; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B·E·C
AB	BCW60B	SAMS	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 350\text{ мВт}; h_{21} = 180...310; f_T > 125\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B·E·C
AB	BCW60B	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 180...310; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B·E·C
ABA	CMPD4150	CSI	dih	$I_C = 250\text{ мА}; V_{BR} = 50\text{ В}; V_{I(f)} = 100\text{ мА} - 0.82...0.92\text{ В}; I_B < 100\text{ нА}; I_{RR} < 4.0\text{ нС}; C_T < 4.0\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A·n.c.·K
ABA	MAX803MXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
ABA	TMPD4150	ALLEG	d	$I_C < 600\text{ мА}; V_{BR} > 75\text{ В}; V_{I(f)} = 1\text{ мА} < 0.62\text{ В}; I_B < 100\text{ нА}; I_{RR} < 4.0\text{ нС}; C_0 < 2.5\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A·n.c.·K
ABAA	MAX809MUR	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 100\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND·RST·V _{CC}
ABB	MAX803TXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
ABC	MAX803SXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
ABC	TMPD4154	ALLEG	d	$I_C < 600\text{ мА}; V_{BR} > 35\text{ В}; V_{I(f)} = 30\text{ мА} < 1.0\text{ В}; I_B < 100\text{ нА}; I_{RR} < 4.0\text{ нС}; C_0 < 4.0\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A·n.c.·K
ABD	MAX803RXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
ABE	MAX803ZXR	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND·RST·V _{CC}
ABF	LM4041AIX3-1.2	MAX	vref	$V_{OUT} = 1.225\text{ В}; \text{ACC} = 0.1\%$	SOT323,SC70	+++·n.c.
ABG	LM4041BIX3-1.2	MAX	vref	$V_{OUT} = 1.225\text{ В}; \text{ACC} = 0.2\%$	SOT323,SC70	+++·n.c.
ABH	LM4041CIX3-1.2	MAX	vref	$V_{OUT} = 1.225\text{ В}; \text{ACC} = 0.5\%$	SOT323,SC70	+++·n.c.
ABI	LM4041DIX3-1.2	MAX	vref	$V_{OUT} = 1.225\text{ В}; \text{ACC} = 1.0\%$	SOT323,SC70	+++·n.c.
ABJ	LM4040AIX3-2.1	MAX	vref	$V_{OUT} = 2.048\text{ В}; \text{ACC} = 0.1\%$	SOT323,SC70	+++·n.c.
ABK	LM4040BIX3-2.1	MAX	vref	$V_{OUT} = 2.048\text{ В}; \text{ACC} = 0.2\%$	SOT323,SC70	+++·n.c.
ABL	LM4040CIX3-2.1	MAX	vref	$V_{OUT} = 2.048\text{ В}; \text{ACC} = 0.5\%$	SOT323,SC70	+++·n.c.



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
ABM	LM4040DIX3-2.1	MAX	vref	$V_{OUT}=2.048\text{ В}$; $ACC=1.0\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ABN	LM4040AIX3-2.5	MAX	vref	$V_{OUT}=2.500\text{ В}$; $ACC=0.1\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ABO	LM4040BIX3-2.5	MAX	vref	$V_{OUT}=2.500\text{ В}$; $ACC=0.2\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ABP	BCW60B	PHIL	npn	$V_{CEB0}=32\text{ В}$; $I_C=200\text{ мА}$; $P_D=250\text{ мВт}$; $h_{21}=180...320$; $f_T>100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	В+Е+С
ABP	LM4040CIX3-2.5	MAX	vref	$V_{OUT}=2.500\text{ В}$; $ACC=0.5\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ABO	LM4040DIX3-2.5	MAX	vref	$V_{OUT}=2.500\text{ В}$; $ACC=1.0\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ABR	LM4040AIX3-3.0	MAX	vref	$V_{OUT}=3.000\text{ В}$; $ACC=0.1\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ABs	BCW60B	SIEM	npn	$V_{CEB0}=32\text{ В}$; $I_C=100\text{ мА}$; $P_D=330\text{ мВт}$; $h_{21}=180...310$; $f_T=250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	В+Е+С
ABS	LM4040BIX3-3.0	MAX	vref	$V_{OUT}=3.000\text{ В}$; $ACC=0.2\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ABt	BCW60B	PHIL	npn	$V_{CEB0}=32\text{ В}$; $I_C=200\text{ мА}$; $P_D=250\text{ мВт}$; $h_{21}=180...320$; $f_T>100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	В+Е+С
ABT	LM4040CIX3-3.0	MAX	vref	$V_{OUT}=3.000\text{ В}$; $ACC=0.5\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ABU	LM4040DIX3-3.0	MAX	vref	$V_{OUT}=3.000\text{ В}$; $ACC=1.0\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ABV	LM4040AIX3-4.1	MAX	vref	$V_{OUT}=4.096\text{ В}$; $ACC=0.1\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ABW	LM4040BIX3-4.1	MAX	vref	$V_{OUT}=4.096\text{ В}$; $ACC=0.2\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ABX	LM4040CIX3-4.1	MAX	vref	$V_{OUT}=4.096\text{ В}$; $ACC=0.5\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ABY	LM4040DIX3-4.1	MAX	vref	$V_{OUT}=4.096\text{ В}$; $ACC=1.0\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ABZ	LM4040AIX3-5.0	MAX	vref	$V_{OUT}=5.000\text{ В}$; $ACC=0.1\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
AC	2SD1101	REN	nnp	$V_{CEB0}=25\text{ В}$; $I_C=700\text{ мА}$; $P_D=150\text{ мВт}$; $h_{21}=120...240$	SOT23,SOD23	В+Е+С
AC	BCW60C	ALLEG	nnp	$V_{CEB0}=32\text{ В}$; $I_{CB0}<20\text{ мА}$; $h_{21}=250...460$; $V_{CEsat}<0.35\text{ В}$; $f_T>125\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	В+Е+С
AC	BCW60C	CDIL	nnp	$V_{CEB0}=32\text{ В}$; $I_C=200\text{ мА}$; $P_D=330\text{ мВт}$; $h_{21}=250...460$; $f_T>250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	В+Е+С
AC	BCW60C	SAMS	nnp	$V_{CEB0}=32\text{ В}$; $I_C=100\text{ мА}$; $P_D=350\text{ мВт}$; $h_{21}=250...460$; $f_T>125\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	В+Е+С
AC	BCW60C	ZETEX	nnp	$V_{CEB0}=32\text{ В}$; $I_C=200\text{ мА}$; $P_D=330\text{ мВт}$; $h_{21}=250...460$; $f_T>250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	В+Е+С
ACA	LM4040BIX3-5.0	MAX	vref	$V_{OUT}=5.000\text{ В}$; $ACC=0.2\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ACAA	MAX809TUR	MAX	mrc	$V_{TH}=3.08\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<100\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
ACB	LM4040CIX3-5.0	MAX	vref	$V_{OUT}=5.000\text{ В}$; $ACC=0.5\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ACC	LM4040DIX3-5.0	MAX	vref	$V_{OUT}=5.000\text{ В}$; $ACC=1.0\%$	SOT323,SC70	+++n.c.
ACD	MAX6808XR32	MAX	vd	$V_{TH}=3.2\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<80\text{ мкА}$	SOT323,SC70	RST-GND- V_{CC}
ACE	MAX6326XR31	MAX	mrc	$V_{TH}=3.08\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND-RST- V_{CC}
ACF	MAX6347XR46	MAX	mrc	$V_{TH}=4.6\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND-RST- V_{CC}
ACH	MAX6326XR23	MAX	mrc	$V_{TH}=2.32\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND-RST- V_{CC}
ACI	MAX6326XR26	MAX	mrc	$V_{TH}=2.63\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND-RST- V_{CC}
ACJ	MAX6328XR26	MAX	mrc	$V_{TH}=2.63\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND-RST- V_{CC}
ACK	MAX6346XR44	MAX	mrc	$V_{TH}=4.38\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND-RST- V_{CC}
ACL	2SC3837KL	ROHM	nnp	$V_{CEB0}=30\text{ В}$; $I_C=50\text{ мА}$; $P_D=150\text{ мВт}$; $h_{21}=27...56$; $f_T=1500\text{ МГц}$	SOT346,SC59	В+Е+С
ACL	MAX6347XR44	MAX	mrc	$V_{TH}=4.38\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND-RST- V_{CC}
ACM	2SC3837KM	ROHM	nnp	$V_{CEB0}=30\text{ В}$; $I_C=50\text{ мА}$; $P_D=150\text{ мВт}$; $h_{21}=39...82$; $f_T=1500\text{ МГц}$	SOT346,SC59	В+Е+С
ACM	MAX6348XR44	MAX	mrc	$V_{TH}=4.38\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND-RST- V_{CC}
ACN	2SC3837KN	ROHM	nnp	$V_{CEB0}=30\text{ В}$; $I_C=50\text{ мА}$; $P_D=150\text{ мВт}$; $h_{21}=56...120$; $f_T=1500\text{ МГц}$	SOT346,SC59	В+Е+С
ACN	2SC4725N	ROHM	nnp	$V_{CEB0}=30\text{ В}$; $I_C=50\text{ мА}$; $P_D=150\text{ мВт}$; $h_{21}=56...120$; $f_T=1500\text{ МГц}$	SOT416,SC75A	В+Е+С
ACN	2SC5661N	ROHM	nnp	$V_{CEB0}=30\text{ В}$; $I_C=50\text{ мА}$; $P_D=150\text{ мВт}$; $h_{21}=56...120$; $f_T=1500\text{ МГц}$	VMT3,VMD3	В+Е+С
ACN	MAX6348XR46	MAX	mrc	$V_{TH}=4.6\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND-RST- V_{CC}
ACO	MAX6346XR46	MAX	mrc	$V_{TH}=4.63\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND-RST- V_{CC}
ACP	2SC3837KP	ROHM	nnp	$V_{CEB0}=30\text{ В}$; $I_C=50\text{ мА}$; $P_D=150\text{ мВт}$; $h_{21}=82...180$; $f_T=1500\text{ МГц}$	SOT346,SC59	В+Е+С
ACP	2SC4725P	ROHM	nnp	$V_{CEB0}=30\text{ В}$; $I_C=50\text{ мА}$; $P_D=150\text{ мВт}$; $h_{21}=82...180$; $f_T=1500\text{ МГц}$	SOT416,SC75A	В+Е+С
ACP	2SC5661P	ROHM	nnp	$V_{CEB0}=30\text{ В}$; $I_C=50\text{ мА}$; $P_D=150\text{ мВт}$; $h_{21}=82...180$; $f_T=1500\text{ МГц}$	VMT3,VMD3	В+Е+С
ACp	BCW60C	PHIL	nnp	$V_{CEB0}=32\text{ В}$; $I_C=200\text{ мА}$; $P_D=250\text{ мВт}$; $h_{21}=250...460$; $f_T>100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	В+Е+С
ACP	MAX6326XR29	MAX	mrc	$V_{TH}=2.93\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND-RST- V_{CC}
ACQ	2SC3837KQ	ROHM	nnp	$V_{CEB0}=30\text{ В}$; $I_C=50\text{ мА}$; $P_D=150\text{ мВт}$; $h_{21}=120...270$; $f_T=1500\text{ МГц}$	SOT346,SC59	В+Е+С
ACQ	MAX6327XR23	MAX	mrc	$V_{TH}=2.32\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND-RST- V_{CC}
ACR	MAX6377XR24	MAX	vd	$V_{TH}=2.40\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND-OUT- V_{CC}
ACR	MAX6327XR26	MAX	mrc	$V_{TH}=2.63\text{ В}$; $V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT323,SC70	GND-RST- V_{CC}
ACs	BCW60C	SIEM	nnp	$V_{CEB0}=32\text{ В}$; $I_C=100\text{ мА}$; $P_D=330\text{ мВт}$; $h_{21}=250...460$; $f_T=250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	В+Е+С

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
ACS	MAX6327XR29	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-RST-V _{CC}
ACI	BCW60C	PHIL	npn	$V_{CEB} = 32 В; I_C = 200 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 250...460; f_T > 100 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
ACT	MAX6327XR31	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-RST-V _{CC}
ACU	MAX6328XR23	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-RST-V _{CC}
ACV	MAX6328XR29	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-RST-V _{CC}
ACW	MAX6328XR31	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-RST-V _{CC}
ACZ	MAX6375XR26	MAX	vd	$V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
AD	BCW60D	ALLEG	npn	$V_{CEB} = 32 В; I_{CC} < 20 мА; h_{21} = 380...630; V_{CE(sat)} < 0.35 В; f_T > 125 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
AD	BCW60D	CDIL	npn	$V_{CEB} = 32 В; I_C = 100 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 380...630; f_T > 125 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
AD	BCW60D	SAMS	npn	$V_{CEB} = 32 В; I_C = 100 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 380...630; f_T > 125 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
AD	BCW60D	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 32 В; I_C = 200 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 380...630; f_T > 250 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
ADA	MAX6376XR29	MAX	vd	$V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADAA	MAX809SUR	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 100 мкА$	SOT23,SOD23	GND-RST-V _{CC}
ADB	MAX6377XR23	MAX	vd	$V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADC	MAX6377XR29	MAX	vd	$V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADD	MAX6378XR46	MAX	vd	$V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADE	MAX6379XR44	MAX	vd	$V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADF	MAX6380XR46	MAX	vd	$V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADI	MAX6375XR22	MAX	vd	$V_{TR} = 2.20 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADI	MAX6375XR23	MAX	vd	$V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADJ	MAX6375XR29	MAX	vd	$V_{TR} = 2.93 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADK	MAX6375XR31	MAX	vd	$V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADL	2SC3839KL	ROHM	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 27...56; f_T = 3200 МГц$	SOT346,SC59	B-E-C
ADL	MAX6376XR22	MAX	vd	$V_{TR} = 2.20 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADM	2SC3839KM	ROHM	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 39...82; f_T = 3200 МГц$	SOT346,SC59	B-E-C
ADM	MAX6376XR23	MAX	vd	$V_{TR} = 2.32 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADN	2SC3839KN	ROHM	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 56...120; f_T = 3200 МГц$	SOT346,SC59	B-E-C
ADN	2SC4726N	ROHM	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 56...120; f_T = 3200 МГц$	SOT416,SC75A	B-E-C
ADN	2SC5662N	ROHM	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 56...120; f_T = 3200 МГц$	VMT3,VMD3	B-E-C
ADN	MAX6376XR26	MAX	vd	$V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADO	MAX6376XR31	MAX	vd	$V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADP	2SC3838KP	ROHM	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 82...180; f_T = 3200 МГц$	SOT346,SC59	B-E-C
ADP	2SC4726P	ROHM	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 82...180; f_T = 3200 МГц$	SOT416,SC75A	B-E-C
ADP	2SC5662P	ROHM	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 82...180; f_T = 3200 МГц$	VMT3,VMD3	B-E-C
ADp	BCW60D	PHIL	npn	$V_{CEB} = 32 В; I_C = 200 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 380...630; f_T > 100 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
ADQ	MAX6377XR22	MAX	vd	$V_{TR} = 2.20 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADQ	2SC3839KQ	ROHM	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 120...270; f_T = 3200 МГц$	SOT346,SC59	B-E-C
ADR	MAX6377XR26	MAX	vd	$V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADR	MAX6377XR31	MAX	vd	$V_{TR} = 3.08 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADs	BCW60D	SIEM	npn	$V_{CEB} = 32 В; I_C = 100 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 380...630; f_T > 250 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
ADs	MAX6378XR44	MAX	vd	$V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADT	BCW60D	PHIL	npn	$V_{CEB} = 32 В; I_C = 200 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 380...630; f_T > 100 МГц$	SOT23,SOD23	B-E-C
ADT	MAX6379XR46	MAX	vd	$V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADU	MAX6380XR44	MAX	vd	$V_{TR} = 4.38 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADW	MAX6380XR42	MAX	vd	$V_{TR} = 4.20 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADX	MAX6375XR28	MAX	vd	$V_{TR} = 2.80 В; V_{DD} = 1.2...5.5 В; I_{CC} < 1.75 мкА$	SOT323,SC70	GND-OUT-V _{CC}
ADY	MAX6381XR1D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.58 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 13 мкА$	SOT323,SC70	GND-RST-V _{CC}
ADZ	MAX6382XR26D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 13 мкА$	SOT323,SC70	GND-RST-V _{CC}
AEA	MAX6383XR17D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.67 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 13 мкА$	SOT323,SC70	GND-RST-V _{CC}
AEB	MAX6381XR46D2	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63 В; V_{DD} = 1...5.5 В; I_{CC} < 13 мкА$	SOT323,SC70	GND-RST-V _{CC}
AEL	2SC3839KL	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 27...56; f_T > 200 МГц$	SOT346,SC59	B-E-C
AEM	2SC3839KM	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 39...82; f_T > 200 МГц$	SOT346,SC59	B-E-C



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3
AEN	2SC3839KN	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 56...120$; $f_T > 200$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
AEP	2SC3839KP	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 82...180$; $f_T > 200$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
AEQ	2SC3839KQ	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 120...270$; $f_T > 200$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
AFAA	MAX809RUR	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63$ В; $V_{DD} = 1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 100$ мкА	SOT23, SOD23	GND·RST·V _{CC}
AFP	2SD1781KP	ROHM	npn	$V_{CE0} = 40$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 82...180$; $f_T > 150$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
AFQ	2SD1781KQ	ROHM	npn	$V_{CE0} = 40$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 120...270$; $f_T > 150$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
AFR	2SD1781KR	ROHM	npn	$V_{CE0} = 40$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 180...390$; $f_T > 150$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
AFS	BCW60FF	SIEM	npn	$V_{CE0} = 32$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 250...460$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AG	BCX70G	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_{C0} = 20$ мА; $h_{21} = 120...220$; $V_{CE(sat)} < 0.35$ В; $f_T > 125$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AG	BCX70G	CDIL	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 120...220$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AG	BCX70G	SAMS	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 350$ мВт; $h_{21} = 120...220$; $f_T > 125$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AG	BCX70G	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 120...220$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AG	BRA144ECM	REN	Dnpn	$V_{CE} = 50$ В; $I_{CJT} = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} > 70$; 47 к/47 к	SOT323, SC70	В·Е·С
AG	BRA144EMP	REN	Dnpn	$V_{CE} = 50$ В; $I_{CJT} = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} > 70$; 47 к/47 к	SOT23, SOD23	В·Е·С
AGAA	MAX810LUR	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63$ В; $V_{DD} = 1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 100$ мкА	SOT23, SOD23	GND·RST·V _{CC}
AGp	BCX70G	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 120...220$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AGs	BCX70G	SIEM	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 120...220$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AGt	BCX70G	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 120...220$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AH	1SS345	SANYO	shd	$V_B = 55$ В; $V_{E(I=1\text{ mA})} < 0.35$ В; $I_B(V_B = 40\text{ В}) < 50$ мкА; $C_T < 120$ пФ	SOT23, SOD23	A·n.c·K
AH	BCX70H	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_{C0} = 20$ мА; $h_{21} = 180...310$; $V_{CE(sat)} < 0.35$ В; $f_T > 125$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AH	BCX70H	CDIL	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 250...460$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AH	BCX70H	SAMS	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 350$ мВт; $h_{21} = 180...310$; $f_T > 125$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AH	BCX70H	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 180...310$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AHAA	MAX810MUR	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38$ В; $V_{DD} = 1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 100$ мкА	SOT23, SOD23	GND·RST·V _{CC}
AHP	2SB1197KP	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 40$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 82...180$; $f_T > 200$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
AHQ	BCX70H	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 250...460$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AHQ	2SB1197KQ	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 40$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 120...270$; $f_T > 200$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
AHR	2SB1197KR	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 40$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 180...390$; $f_T > 200$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
AHs	BCX70H	SIEM	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 180...310$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AHT	BCX70H	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 250...460$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AJ	BCX70J	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_{C0} = 20$ мА; $h_{21} = 250...460$; $V_{CE(sat)} < 0.35$ В; $f_T > 125$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AJ	BCX70J	CDIL	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 250...460$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AJ	BCX70J	SAMS	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 350$ мВт; $h_{21} = 250...460$; $f_T > 125$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AJ	BCX70J	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 250...460$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AJAA	MAX810TUR	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08$ В; $V_{DD} = 1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 100$ мкА	SOT23, SOD23	GND·RST·V _{CC}
AJP	2SD1782KP	ROHM	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 82...180$; $f_T > 180$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
AJp	BCX70J	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 180...310$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AJQ	2SD1782KQ	ROHM	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 120...270$; $f_T > 180$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
AJR	2SD1782KR	ROHM	npn	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 180...390$; $f_T > 180$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
AJs	BCX70J	SIEM	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 250...460$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AJt	BCX70J	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 180...310$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AK	BCX70K	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_{C0} = 20$ мА; $h_{21} = 380...630$; $V_{CE(sat)} < 0.35$ В; $f_T > 125$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AK	BCX70K	CDIL	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 380...630$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AK	BCX70K	SAMS	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 350$ мВт; $h_{21} = 380...630$; $f_T > 125$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AK	BCX70K	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 380...630$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AKAA	MAX810SUR	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93$ В; $V_{DD} = 1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 100$ мкА	SOT23, SOD23	GND·RST·V _{CC}
AKP	2SB1198KP	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 82...180$; $f_T > 180$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
AKp	BCX70K	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{21} = 380...630$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
AKQ	2SB1198KQ	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 120...270$; $f_T > 180$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
AKR	2SB1198KR	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 80$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 180...390$; $f_T > 180$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
AKs	BCX70K	SIEM	npn	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{21} = 380...630$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
ALAA	MAX810RUR	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63$ В; $V_{DD} = 1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 100$ мкА	SOT23, SOD23	GND·RST·V _{CC}

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
ALM	2SC3802KM	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 30\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 39...82; f_T > 110\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
ALN	2SC3802KN	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 30\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 56...120; f_T > 110\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
ALP	2SC3802KP	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 30\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 82...180; f_T > 110\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
ALQ	2SC3802KQ	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_C = 30\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 120...270; f_T > 110\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
AM	BSS64	MOT	npn	$V_{CEB} = 120\text{ В}; I_C = 800\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 20...80; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
AM	MMBT3904WT1	MOT	npn	$V_{CEB} = 60\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} = 100...300; f_T > 200\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
AMN	2SC4018KN	ROHM	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 56...120; f_T > 230\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
AMP	2SC4018KP	ROHM	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 82...180; f_T > 230\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
AmP	BSS64	PHIL	npn	$V_{CEB} = 120\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 20; f_T > 60$	SOT23, SOD23	B•E•C
AMs	BSS64	SIEM	npn	$V_{CEB} = 120\text{ В}; I_C = 800\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 20...80; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
AMt	BSS64	PHIL	npn	$V_{CEB} = 120\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 20; f_T > 60$	SOT23, SOD23	B•E•C
AN	2SC2413KN	ROHM	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 56...120; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
AN	2SC2532	TOSH	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 300\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 5000$	SOT346, SC59	B•E•C
AN	2SC4098N	ROHM	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 56...120; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
AN	2SC4618N	ROHM	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 56...120; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT416, SC75A	B•E•C
AN	2SC5659N	ROHM	npn	$V_{CEB} = 25\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} = 56...120; f_T > 150\text{ МГц}$	VMT3, VMD3	B•E•C
AN	2SK3287	REN	nMOS	$V_{DS} = 30\text{ В}; I_D = 300\text{ мА}; P_D = 400\text{ мВт}; R_{DS(on)} < 3.44\text{ Ом}$	SOT323, SOD23	G•S•D
AN	2SK3289	REN	nMOS	$V_{DS} = 30\text{ В}; I_D = 300\text{ мА}; P_D = 400\text{ мВт}; R_{DS(on)} < 3.44\text{ Ом}$	SOT323, SC70	G•S•D
ANM	2SC4061KM	ROHM	npn	$V_{CEB} = 300\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 39...82; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
ANN	2SC4061KN	ROHM	npn	$V_{CEB} = 300\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 56...120; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
ANP	2SC4061KP	ROHM	npn	$V_{CEB} = 300\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 82...180; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
ANs	BCW60FN	SIEM	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 380...630; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
ANt	BCW60AR	ITT	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 120...220; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	C•B•E
AP	2SC2413KP	ROHM	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 82...180; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
AP	2SC4098P	ROHM	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 82...180; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
AP	2SC4618P	ROHM	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 82...180; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT416, SC75A	B•E•C
AP	2SC5659P	ROHM	npn	$V_{CEB} = 25\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} = 82...180; f_T > 150\text{ МГц}$	VMT3, VMD3	B•E•C
AP	2SJ575	REN	pMOS	$V_{DS} = 30\text{ В}; I_D = 100\text{ мА}; P_D = 400\text{ мВт}; R_{DS(on)} < 7.9\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G•S•D
AP	2SJ576	REN	pMOS	$V_{DS} = 30\text{ В}; I_D = 100\text{ мА}; P_D = 400\text{ мВт}; R_{DS(on)} < 7.9\text{ Ом}$	SOT23, SC70	G•S•D
AP	BCW60BR	ITT	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 180...310; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	C•B•E
AP	2SC4074K	ROHM	npn	$V_{CEB} = 18\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 270; f_T > 1500\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
AQ	2SC2413KQ	ROHM	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 120...270; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
AQ	2SC4098Q	ROHM	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 120...270; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT323, SOD23	C•B•E
AQ	2SC4618Q	ROHM	npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 120...270; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT416, SC75A	B•E•C
AQ	2SC5659Q	ROHM	npn	$V_{CEB} = 25\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} = 120...270; f_T > 150\text{ МГц}$	VMT3, VMD3	B•E•C
A-Q	2PD1820AQ	PHIL	npn	$V_{CEB} = 60\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 85...170; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
A-Q	2PD1820AR	PHIL	npn	$V_{CEB} = 60\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 120...240; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
AQP	2SB1051KQ	ROHM	pnP	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 1000\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 82...180; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
AQQ	2SB1051KQ	ROHM	pnP	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 1000\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 120...270; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
AQR	2SB1051KR	ROHM	pnP	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 1000\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 180...390; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT346, SC59	B•E•C
AR	BCW60CR	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 250...460; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
AR	BCW60CR	ITT	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 250...460; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	C•B•E
AR	MSD709R	MOT	pnP	$V_{CEB} = 25\text{ В}$	SOT23, SOD23	B•E•C
AS	2SA1655	SANYO	pnP	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 30; f_T > 200\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
AS	BAT1805	SIEM	cpm-2	$V_{FS} = 35\text{ В}; I_F < 100\text{ мА}; V_{F1} = 100\text{ мА} < 1.2\text{ В}; I_S < 0.02\text{ мА}; C_C < 1.0\text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1•K2
AS	BCW600R	ITT	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт}; h_{21} = 380...630; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	C•B•E
AS	MSD709S	MOT	pnP	$V_{CEB} = 25\text{ В}$	SOT23, SOD23	B•E•C
A-S	2PD1820AS	PHIL	npn	$V_{CEB} = 60\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 170...340; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
ASA	BC846UA	AUK	npn	$V_{CEB} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
ASB	BC846UB	AUK	npn	$V_{CEB} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
ASC	BC846UC	AUK	npn	$V_{CEB} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 420...800; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
ASG	KTA1504	KEC	pnP	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 150\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 200...400; f_T > 80\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	КБ	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
ASO	KTA1504	KEC	pinp	$V_{CBO} > 50$ В; $I_C < 150$ мА; $P_D < 150$ мВт; $h_{21} > 70$...140; $f_T > 80$ МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
AS5	BAT18-05	INF	cpin-2	$V_A < 35$ В; $I_C < 100$ мА; $V_{F(I_F=100 \mu A)} < 1.2$ В; $I_S < 0.02$ мкА; $C_0 < 1.0$ нФ	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
ASY	KTA1504	KEC	pinp	$V_{CBO} > 50$ В; $I_C < 150$ мА; $P_D < 150$ мВт; $h_{21} > 120$...240; $f_T > 80$ МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
AT	BAT1806	SIEM	cpin-2	$V_A < 35$ В; $I_C < 100$ мА; $V_{F(I_F=100 \mu A)} < 1.2$ В; $I_S < 0.02$ мкА; $C_0 < 1.0$ нФ	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
AIQ	2PD1820AQ	PHIL	nnp	$V_{CBO} > 60$ В; $I_C < 500$ мА; $P_D < 200$ мВт; $h_{21} > 85$...170; $f_T > 150$ МГц	SOT323, SC70	B•E•C
AIQ	2PD1820AR	PHIL	nnp	$V_{CBO} > 60$ В; $I_C < 500$ мА; $P_D < 200$ мВт; $h_{21} > 120$...240; $f_T > 150$ МГц	SOT323, SC70	B•E•C
ATQ	2SC4326KQ	ROHM	nnp	$V_{CBO} > 12$ В; $I_C < 50$ мА; $P_D < 150$ мВт; $h_{21} > 120$...270; $f_T > 800$ МГц	SOT346, SC59	B•E•C
ATR	2SC4326KR	ROHM	nnp	$V_{CBO} > 12$ В; $I_C < 50$ мА; $P_D < 150$ мВт; $h_{21} > 180$...390; $f_T > 800$ МГц	SOT346, SC59	B•E•C
AIS	2PD1820AS	PHIL	nnp	$V_{CBO} > 60$ В; $I_C < 500$ мА; $P_D < 200$ мВт; $h_{21} > 170$...340; $f_T > 150$ МГц	SOT323, SC70	B•E•C
ATS	2SC4326KS	ROHM	nnp	$V_{CBO} > 12$ В; $I_C < 50$ мА; $P_D < 150$ мВт; $h_{21} > 270$...560; $f_T > 800$ МГц	SOT346, SC59	B•E•C
ATs	BAT18-06	SIEM	cpin-2	$V_A < 35$ В; $I_C < 100$ мА; $V_{F(I_F=100 \mu A)} < 1.2$ В; $I_S < 0.02$ мкА; $C_0 < 1.0$ нФ	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
AU	BAT1804	SIEM	cpin-2	$V_A < 35$ В; $I_C < 100$ мА; $V_{F(I_F=100 \mu A)} < 1.2$ В; $I_S < 0.02$ мкА; $C_0 < 1.0$ нФ	SOT23, SOD23	A1•K2•K1, A2
AUs	BAT18-04	INF	cpin-2	$V_A < 35$ В; $I_C < 100$ мА; $V_{F(I_F=100 \mu A)} < 1.2$ В; $I_S < 0.02$ мкА; $C_0 < 1.0$ нФ	SOT23, SOD23	A1•K2•K1, A2
AV	DAN212K	ROHM	di	$V_A < 70$ В; $I_C < 200$ мА; $P_D < 250$ мВт; $V_{F(I_F=150 \mu A)} < 1.25$ В; $I_S < 4$ нС	SOT323, SOD23	A•n.c. • K
AW	BCX70GR	ZETEX	nnp	$V_{CBO} > 45$ В; $I_C < 200$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} > 120$...220; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
AX	BCX70JR	ZETEX	nnp	$V_{CBO} > 45$ В; $I_C < 200$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} > 250$...460; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
AY	BCX70UR	ITT	nnp	$V_{CBO} > 45$ В; $I_C < 200$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} > 250$...460; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	C•B•E
AY	BCX70KR	ITT	nnp	$V_{CBO} > 45$ В; $I_C < 200$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} > 380$...630; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	C•B•E
AY	MMBD1000LT1	MOT	di	$V_A < 20$ В; $I_C < 200$ мА; $V_{F(I_F=10 \mu A)} < 0.95$ В; $C_0 < 2$ нФ; $t_{RR} < 3$ нС	SOT23, SOD23	A•n.c. • K
AYAA	MAX6120EUR	MAX	wref	$V_{IN} > 2.4$...11 В; $I_{CC} < 70$ мкА; $V_{OUT} > 1.2$ В	SOT23, SOD23	VIN•VOUT•GND
AZO	KTA1505	KEC	pinp	$V_{CBO} > 35$ В; $I_C < 500$ мА; $P_D < 150$ мВт; $h_{21} > 70$...140; $f_T > 200$ МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
AZY	KTA1505	KEC	pinp	$V_{CBO} > 35$ В; $I_C < 500$ мА; $P_D < 150$ мВт; $h_{21} > 120$...240; $f_T > 200$ МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
B	IRLML2803	IR	nMOS	HEXFET; $V_{DS} > 30$ В; $I_D > 0.9$ А; $P_D < 540$ мВт; $R_{\theta DS(j-c)}$ 0.4 Ом	SOT23, SOD23	G•S•D
B	IRF957T1	MOT	nnp	$V_{CBO} > 20$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 227$ мВт; $h_{21} > 50$...200; $f_T > 9$ ГГц	SOT323, SC70	B•E•C
B0	HSMS2810	HP	shd	$V_{BR} > 20$ В; $V_{F(I_F=35 \mu A)} < 1.0$ В; $I_S(V_A=15$ В) < 200 нА; $C_0 < 1.2$ нФ	SOT23, SOD23	A•n.c. • K
B0	HSMS281B	HP	shd	$V_{BR} > 20$ В; $V_{F(I_F=35 \mu A)} < 1.0$ В; $I_S(V_A=15$ В) < 200 нА; $C_0 < 1.2$ нФ	SOT323, SC70	A•n.c. • K
B0	SST5460	SIL	pFET	$V_{DS} > 40$ В; $P_D < 350$ мВт; $I_{OSS} > 1.5$...5 мА; $g_m > 1$ мСм	SOT23, SOD23	D•S•G
B1	HSMS2811	HP	shd	$V_{BR} > 20$ В; $V_{F(I_F=35 \mu A)} < 1.0$ В; $I_S(V_A=15$ В) < 200 нА; $C_0 < 1.2$ нФ	SOT23, SOD23	n.c. • A • K
B1	SST5461	SIL	pFET	$V_{DS} > 40$ В; $P_D < 350$ мВт; $I_{OSS} > 4$ мА; $g_m > 1$ мСм	SOT23, SOD23	D•S•G
B10	KSC2715	SAMS	nnp	$V_{CBO} > 35$ В; $I_C < 50$ мА; $P_D < 150$ мВт; $h_{21} > 70$...140; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
B1R	KSC2715	SAMS	nnp	$V_{CBO} > 35$ В; $I_C < 50$ мА; $P_D < 150$ мВт; $h_{21} > 40$...80; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
B1Y	KSC2715	SAMS	nnp	$V_{CBO} > 35$ В; $I_C < 50$ мА; $P_D < 150$ мВт; $h_{21} > 120$...240; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
B2	BSV52	ZETEX	nnp	$V_{CBO} > 20$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} > 40$...120; $f_T > 500$ МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
B2	BSV52LT1	MOT	nnp	$V_{CBO} > 20$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 300$ мВт; $h_{21} > 40$...120; $f_T > 400$ МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
B2	HSMS2812	HP	shd-2	$V_{BR} > 20$ В; $V_{F(I_F=35 \mu A)} < 1.0$ В; $I_S(V_A=15$ В) < 200 нА; $C_0 < 1.2$ нФ	SOT23, SOD23	A1•K2•K1, A2
B2	HSMS281C	HP	shd-2	$V_{BR} > 20$ В; $V_{F(I_F=35 \mu A)} < 1.0$ В; $I_S(V_A=15$ В) < 200 нА; $C_0 < 1.2$ нФ	SOT323, SC70	A1•K2•K1, A2
B2	SST5462	SIL	pFET	$V_{DS} > 40$ В; $P_D < 350$ мВт; $I_{OSS} > 4$...16 мА; $g_m > 2$ мСм	SOT23, SOD23	D•S•G
B26	BF570	PHIL	nnp	$V_{CBO} > 40$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 250$ мВт; $h_{21} > 40$; $f_T > 490$ МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
B2p	BSV52	PHIL	nnp	$V_{CBO} > 20$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 250$ мВт; $h_{21} > 40$...120; $f_T > 400$	SOT23, SOD23	B•E•C
B2l	BSV52	PHIL	nnp	$V_{CBO} > 20$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 250$ мВт; $h_{21} > 40$...120; $f_T > 400$	SOT23, SOD23	B•E•C
B3	1PS301	PHIL	fd-2	$V_A < 80$ В; $I_C < 250$ мА; $V_{F(I_F=50 \mu A)} < 1.0$ В; $C_0 < 1.5$ нФ; $t_{RR} < 4$ нС	SOT323, SC70	A1•A2•K1, K2
B3	1SS184	TOSH	di-2	$V_A < 80$ В; $I_C < 100$ мА; $V_{F(I_F=100 \mu A)} < 1.2$ В; $I_S < 0.5$ мкА; $t_{RR} < 4$ нС	SOT346, SC59	A1•A2•K1, K2
B3	1SS301	TOSH	di-2	$V_A < 80$ В; $I_C < 100$ мА; $V_{F(I_F=100 \mu A)} < 1.2$ В; $t_{RR} < 4$ нС	SOT23, SC70	A1•A2•K1, K2
B3	1SS361	TOSH	di-2	$V_A < 80$ В; $I_C < 100$ мА; $V_{F(I_F=100 \mu A)} < 1.2$ В; $I_S < 0.5$ мкА; $t_{RR} < 4$ нС	SOT416, SC75A	A1•A2•K1, K2
B3	1SS361F	TOSH	di-2	$V_A < 80$ В; $I_C < 100$ мА; $V_{F(I_F=100 \mu A)} < 1.2$ В; $I_S < 0.5$ мкА; $t_{RR} < 4$ нС	SOT490, SC89	A1•A2•K1, K2
B3	HSMS2813	HP	shd-2	$V_{BR} > 20$ В; $V_{F(I_F=35 \mu A)} < 1.0$ В; $I_S(V_A=15$ В) < 200 нА; $C_0 < 1.2$ нФ	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
B3	HSMS281E	HP	shd-2	$V_{BR} > 20$ В; $V_{F(I_F=35 \mu A)} < 1.0$ В; $I_S(V_A=15$ В) < 200 нА; $C_0 < 1.2$ нФ	SOT323, SC70	K1•K2•A2, A1
B3	MMBD171LT1	MOT	shd-2	$V_A > 20$ В; $V_{F(I_F=1 \text{ mA})} < 0.37$ В; $C_T < 2.5$ нФ	SOT323, SC70	K1•K2•A1, A2
B31	IDB31	GS	btld	$V_{BR} > 30$...34 В; $I_{FRM} > 2$ А; $P_D < 150$ мВт	SOT23, SOD23	x•x•n.c.
B4	BSV52R	PHIL	nnp	$V_{CBO} > 12$ В; $I_C < 200$ мА; $P_D < 200$ мВт; $h_{21} > 40$; $f_T > 400$	SOT23, SOD23	E•B•C
B4	BSV52R	ZETEX	nnp	$V_{CBO} > 20$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} > 40$...120; $f_T > 500$ МГц	SOT23, SOD23	B•E•C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3
VMD3



SOT416
SOT523

SOT323
SOT346

SOT23-3
SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
B4	HSM52814	HP	shd-2	$V_{BR} > 20B$; $V_{F(I_F=35\text{ mA})} < 1.0B$; $I_H(V_H=15B) < 200\text{ nA}$; $C_D < 1.2\text{ nF}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
B4	HSM5281F	HP	shd-2	$V_{BR} > 20B$; $V_{F(I_F=35\text{ mA})} < 1.0B$; $I_H(V_H=15B) < 200\text{ nA}$; $C_D < 1.2\text{ nF}$	SOT323,SC70	A1-A2-K2,K1
B5s	BV585-05W	INF	var	$V_{F(I_F=10B)}$; $I_C < 20\text{ mA}$; $I_B < 0.01\text{ mA}$; $C_{T1} = 17.5...19.3\text{ nF}$; $C_{B6} = 5.5...6.6\text{ nF}$	SOT323,SC70	A1-A2-K1,K2
B6	2SB81586	SANYO	pnp	$V_{CEB} > 20B$; $I_C < 700\text{ mA}$; $P_D < 200\text{ mВт}$; $h_{21} > 200...400$; $f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
B6	BAT54A	ZOWIE	shd-2	$V_{F(I_F=30\text{ mA})}$; $V_{F(I_F=300\text{ mA})} < 500\text{ mВ}$; $C_D < 10\text{ nF}$; $t_{RR} < 5\text{ нс}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
B6s	BV585-06W	INF	var	$V_{F(I_F=10B)}$; $I_C < 20\text{ mA}$; $I_B < 0.01\text{ mA}$; $C_{T1} = 17.5...19.3\text{ nF}$; $C_{B6} = 5.5...6.6\text{ nF}$	SOT323,SC70	K1-K2-A1,A2
B7	2SB81587	SANYO	pnp	$V_{CEB} > 20B$; $I_C < 700\text{ mA}$; $P_D < 200\text{ mВт}$; $h_{21} > 300...600$; $f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
B9	1SS311	TOSH	di	$V_{F(I_F=400B)}$; $I_C < 100\text{ mA}$; $V_{F(I_F=100\text{ mA})} < 1.2B$; $I_B < 1.0\text{ mA}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
B9	1SS397	TOSH	di	$V_{F(I_F=400B)}$; $I_C < 100\text{ mA}$; $V_{F(I_F=100\text{ mA})} < 1.3B$	SOT323,SC70	A-n.c.-K
B9	2SC4617	ON	nnpn	$V_{CEB} > 50B$; $I_C < 100\text{ mA}$; $P_D < 125\text{ mВт}$; $h_{21} > 120...560$; $f_T > 180\text{ МГц}$	SOT416,SC75A	B-E-C
BA	1SS154	TOSH	shd	$V_{F(I_F=6B)}$; $I_C < 30\text{ mA}$; $V_{F(I_F=10\text{ mA})} < 0.5B$; $I_B < 0.5\text{ mA}$	SOT346,SC59	A-n.c.-A-K
BA	BCW61A	ALLEG	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 20\text{ mA}$; $h_{21} > 120...220$; $V_{CE(sat)} < 0.25B$	SOT23,SOD23	B-E-C
BA	BCW61A	CDIL	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 200\text{ mA}$; $P_D < 330\text{ mВт}$; $h_{21} > 120...220$; $f_T > 180\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BA	BCW61A	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 100\text{ mA}$; $P_D < 350\text{ mВт}$; $h_{21} > 120...220$	SOT23,SOD23	B-E-C
BA	BCW61A	ZETEX	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 200\text{ mA}$; $P_D < 330\text{ mВт}$; $h_{21} > 120...220$; $f_T > 180\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BA	DAN217	ROHM	di-2	$V_{F(I_F=80B)}$; $I_C < 100\text{ mA}$; $P_D < 200\text{ mВт}$; $V_{F(I_F=100\text{ mA})} < 1.2B$	SOT346,SC59	A1-K2-K1,A2
BAp	BCW61A	PHIL	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 200\text{ mA}$; $P_D < 250\text{ mВт}$; $h_{21} > 120...220$; $f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BAs	BCW61A	SIEM	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 100\text{ mA}$; $P_D < 330\text{ mВт}$; $h_{21} > 120...220$; $f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BAI	BCW61A	PHIL	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 200\text{ mA}$; $P_D < 250\text{ mВт}$; $h_{21} > 120...220$; $f_T > 100\text{ МГц}$	A-n.c.-C	
BB	1SV128	TOSH	psh	$V_{F(I_F=50B)}$; $I_C < 50\text{ mA}$; $V_{F(I_F=50\text{ mA})} < 0.95B$; $I_B < 0.1\text{ mA}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
BB	2SB831B	REN	pnp	$V_{CEB} > 25B$; $I_C < 700\text{ mA}$; $P_D < 150\text{ mВт}$; $h_{21} > 85...170$	SOT23,SOD23	B-E-C
BB	BCW61B	ALLEG	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 20\text{ mA}$; $h_{21} > 180...310$; $V_{CE(sat)} < 0.25B$	SOT23,SOD23	B-E-C
BB	BCW61B	CDIL	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 200\text{ mA}$; $P_D < 330\text{ mВт}$; $h_{21} > 180...310$; $f_T > 180\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BB	BCW61B	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 100\text{ mA}$; $P_D < 350\text{ mВт}$; $h_{21} > 180...310$	SOT23,SOD23	B-E-C
BB	BCW61B	ZETEX	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 200\text{ mA}$; $P_D < 330\text{ mВт}$; $h_{21} > 180...310$; $f_T > 180\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BBp	BCW61B	PHIL	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 200\text{ mA}$; $P_D < 250\text{ mВт}$; $h_{21} > 180...310$; $f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BBs	BCW61B	SIEM	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 100\text{ mA}$; $P_D < 330\text{ mВт}$; $h_{21} > 180...310$; $f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BBt	BCW61B	PHIL	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 200\text{ mA}$; $P_D < 250\text{ mВт}$; $h_{21} > 180...310$; $f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BBU	2SD2114KU	ROHM	nnpn	$V_{CEB} > 25B$; $I_C < 500\text{ mA}$; $P_D < 200\text{ mВт}$; $h_{21} > 560...1200$; $f_T > 350\text{ МГц}$	SOT346,SC59	B-E-C
BBV	2SD2114KV	ROHM	nnpn	$V_{CEB} > 25B$; $I_C < 500\text{ mA}$; $P_D < 200\text{ mВт}$; $h_{21} > 620...1800$; $f_T > 350\text{ МГц}$	SOT346,SC59	B-E-C
BBW	2SD2114KW	ROHM	nnpn	$V_{CEB} > 25B$; $I_C < 500\text{ mA}$; $P_D < 200\text{ mВт}$; $h_{21} > 1200...2700$; $f_T > 350\text{ МГц}$	SOT346,SC59	B-E-C
BC	2SB831C	REN	pnp	$V_{CEB} > 25B$; $I_C < 700\text{ mA}$; $P_D < 150\text{ mВт}$; $h_{21} > 120...240$	SOT23,SOD23	B-E-C
BC	BCW61C	ALLEG	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 20\text{ mA}$; $h_{21} > 250...460$; $V_{CE(sat)} < 0.25B$	SOT23,SOD23	B-E-C
BC	BCW61C	CDIL	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 200\text{ mA}$; $P_D < 330\text{ mВт}$; $h_{21} > 250...460$; $f_T > 180\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BC	BCW61C	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 100\text{ mA}$; $P_D < 350\text{ mВт}$; $h_{21} > 250...460$; $f_T > 125\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BC	BCW61C	ZETEX	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 200\text{ mA}$; $P_D < 330\text{ mВт}$; $h_{21} > 250...460$; $f_T > 180\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BCp	BCW61C	PHIL	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 200\text{ mA}$; $P_D < 250\text{ mВт}$; $h_{21} > 250...460$; $f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BCs	BCW61C	SIEM	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 100\text{ mA}$; $P_D < 330\text{ mВт}$; $h_{21} > 250...460$; $f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BCl	BCW61C	PHIL	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 200\text{ mA}$; $P_D < 250\text{ mВт}$; $h_{21} > 250...460$; $f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BD	1SS271	TOSH	shd-2	$V_{F(I_F=6B)}$; $I_C < 30\text{ mA}$; $V_{F(I_F=10\text{ mA})} < 0.5B$; $I_B < 0.5\text{ mA}$	SOT346,SC59	A1-K2-K1,A2
BD	BCW61D	ALLEG	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 20\text{ mA}$; $h_{21} > 380...630$; $V_{CE(sat)} < 0.25B$	SOT23,SOD23	B-E-C
BD	BCW61D	CDIL	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 200\text{ mA}$; $P_D < 330\text{ mВт}$; $h_{21} > 380...630$; $f_T > 180\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BD	BCW61D	SAMS	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 100\text{ mA}$; $P_D < 350\text{ mВт}$; $h_{21} > 380...630$; $f_T > 125\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BD	BCW61D	ZETEX	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 200\text{ mA}$; $P_D < 330\text{ mВт}$; $h_{21} > 380...630$; $f_T > 180\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BDM	2SA1733KM	ROHM	pnp	$V_{CEB} > 30B$; $I_C < 30\text{ mA}$; $P_D < 200\text{ mВт}$; $h_{21} > 39...82$; $f_T > 400\text{ МГц}$	SOT346,SC59	B-E-C
BDM	2SA1808M	ROHM	pnp	$V_{CEB} > 30B$; $I_C < 30\text{ mA}$; $P_D < 200\text{ mВт}$; $h_{21} > 39...82$; $f_T > 400\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
BDM	2SA1733KN	ROHM	pnp	$V_{CEB} > 30B$; $I_C < 30\text{ mA}$; $P_D < 200\text{ mВт}$; $h_{21} > 56...120$; $f_T > 400\text{ МГц}$	SOT346,SC59	B-E-C
BDM	2SA1808N	ROHM	pnp	$V_{CEB} > 30B$; $I_C < 30\text{ mA}$; $P_D < 200\text{ mВт}$; $h_{21} > 56...120$; $f_T > 400\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
BDP	2SA1733KP	ROHM	pnp	$V_{CEB} > 30B$; $I_C < 30\text{ mA}$; $P_D < 200\text{ mВт}$; $h_{21} > 82...180$; $f_T > 400\text{ МГц}$	SOT346,SC59	B-E-C
BDP	2SA1808P	ROHM	pnp	$V_{CEB} > 30B$; $I_C < 30\text{ mA}$; $P_D < 200\text{ mВт}$; $h_{21} > 82...180$; $f_T > 400\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
BDr	BCW61D	PHIL	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 200\text{ mA}$; $P_D < 250\text{ mВт}$; $h_{21} > 380...630$; $f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
BDS	BCW61D	SIEM	pnp	$V_{CEB} > 32B$; $I_C < 100\text{ mA}$; $P_D < 330\text{ mВт}$; $h_{21} > 380...630$; $f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типонаимал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
BD1	BCW61D	PHIL	pnp	$V_{CE0} < 32 \text{ В}$; $I_C < 200 \text{ мА}$; $P_D < 250 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 380$; $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BE	1SV172	TOSH	pin-2	$V_{CE} > 50 \text{ В}$; $I_C < 60 \text{ мА}$; $V_{CE(sat)} < 50 \text{ мА}$; $I_C < 0.95 \text{ В}$; $I_C < 0.1 \text{ мкА}$	SOT346, SC59	A1-K2-K1, A2
BE	1SV252	TOSH	pin-2	$V_{CE} > 50 \text{ В}$; $I_C < 60 \text{ мА}$; $V_{CE(sat)} < 0.98 \text{ В}$; $I_C < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SC70	A1-K2-K1, A2
BE2	MMBZ5221ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 20 \text{ мА}) < 2.28 \dots 2.52 \text{ В}$; $I_{F1} < 100 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BE7	MMBZ5226ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 20 \text{ мА}) < 3.13 \dots 3.47 \text{ В}$; $I_{F1} < 25 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BE9	MMBZ5228ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 20 \text{ мА}) < 3.70 \dots 4.10 \text{ В}$; $I_{F1} < 10 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BF	1SS268	TOSH	di-2	$V_{F1} > 30 \text{ В}$; $I_C < 60 \text{ мА}$; $V_{F1}(I_C < 2 \text{ мА}) < 0.85 \text{ В}$; $I_C < 0.1 \text{ мкА}$	SOT346, SC59	A1-A2-K1, K2
BF	1SS312	TOSH	di	$V_{F1} > 30 \text{ В}$; $I_C < 60 \text{ мА}$; $V_{F1}(I_C < 2 \text{ мА}) < 0.85 \text{ В}$; $I_C < 0.1 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	A-A-K
BF	1SS364	TOSH	di-2	$V_{F1} > 30 \text{ В}$; $I_C < 60 \text{ мА}$; $V_{F1}(I_C < 2 \text{ мА}) < 0.85 \text{ В}$; $I_C < 0.1 \text{ мкА}$	SOT416, SC75A	A1-A2-K1, K2
BF	KDS112	KEC	di-2	$V_{F1} > 30 \text{ В}$; $I_C < 60 \text{ мА}$; $I_C < 0.1 \text{ мкА}$; $C_T < 0.8 \text{ нФ}$	SOT323, SC70	A1-A2-K1, K2
BF1	MMBZ5229ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 20 \text{ мА}) < 4.08 \dots 4.52 \text{ В}$; $I_{F1} < 5 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BF2	MMBZ5230ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 20 \text{ мА}) < 4.46 \dots 4.94 \text{ В}$; $I_{F1} < 5 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BF3	MMBZ5231ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 20 \text{ мА}) < 4.84 \dots 5.36 \text{ В}$; $I_{F1} < 5 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BF4	MMBZ5232ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 20 \text{ мА}) < 5.32 \dots 5.88 \text{ В}$; $I_{F1} < 5 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BF6	MMBZ5234ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 20 \text{ мА}) < 5.89 \dots 6.51 \text{ В}$; $I_{F1} < 5 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BF7	MMBZ5235ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 20 \text{ мА}) < 6.46 \dots 7.14 \text{ В}$; $I_{F1} < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BF8	MMBZ5236ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 20 \text{ мА}) < 7.12 \dots 7.88 \text{ В}$; $I_{F1} < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BF9	MMBZ5237ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 20 \text{ мА}) < 7.79 \dots 8.61 \text{ В}$; $I_{F1} < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BFR	2SC4642KR	ROHM	npn	$V_{CE0} > 50 \text{ В}$; $I_C < 100 \text{ мА}$; $P_D < 200 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 180$; $f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
BFR	2SC4723R	ROHM	npn	$V_{CE0} > 50 \text{ В}$; $I_C < 100 \text{ мА}$; $P_D < 200 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 180$; $f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	B-E-C
BFS	2SC4642KS	ROHM	npn	$V_{CE0} > 50 \text{ В}$; $I_C < 100 \text{ мА}$; $P_D < 200 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 270$; $f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
BFS	2SC4723S	ROHM	npn	$V_{CE0} > 50 \text{ В}$; $I_C < 100 \text{ мА}$; $P_D < 200 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 270$; $f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	B-E-C
BFs	BCW61FF	SIEM	pnip	$V_{CE0} > 32 \text{ В}$; $I_C < 100 \text{ мА}$; $P_D < 330 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 250$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BG	1SS269	TOSH	di-2	$V_{F1} > 30 \text{ В}$; $I_C < 60 \text{ мА}$; $V_{F1}(I_C < 2 \text{ мА}) < 0.85 \text{ В}$; $I_C < 0.1 \text{ мкА}$	SOT346, SC59	K1-K2-A1, A2
BG	1SS313	TOSH	di	$V_{F1} > 30 \text{ В}$; $I_C < 60 \text{ мА}$; $V_{F1}(I_C < 2 \text{ мА}) < 0.85 \text{ В}$; $I_C < 0.1 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	K-K-A
BG	BCX71G	ALLEG	pnip	$V_{CE0} > 45 \text{ В}$; $I_{CBO} < 20 \text{ нА}$; $h_{FE1} > 120$; 220 ; $V_{CE(sat)} < 0.25 \text{ В}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BG	BCX71G	CDIL	pnip	$V_{CE0} > 45 \text{ В}$; $I_C < 200 \text{ мА}$; $P_D < 250 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 120$; $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BG	BCX71G	SAMS	pnip	$V_{CE0} > 45 \text{ В}$; $I_C < 100 \text{ мА}$; $P_D < 350 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 120$; 220	SOT23, SOD23	B-E-C
BG	BCX71G	ZETEX	pnip	$V_{CE0} > 45 \text{ В}$; $I_C < 200 \text{ мА}$; $P_D < 330 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 120$; 220 ; $f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BG	BRC144ECM	REN	Dnnpn	$V_{CE0} > 50 \text{ В}$; $I_{C(sat)} < 100 \text{ мА}$; $P_D < 150 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 70$; 47 к / 47 к	SOT323, SC70	B-E-C
BG	BRC144EMP	REN	Dnnpn	$V_{CE0} > 50 \text{ В}$; $I_{C(sat)} < 100 \text{ мА}$; $P_D < 150 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 70$; 47 к / 47 к	SOT23, SOD23	B-E-C
BG2	MMBZ5239ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 20 \text{ мА}) < 8.65 \dots 9.56 \text{ В}$; $I_{F1} < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BG3	MMBZ5240ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 20 \text{ мА}) < 9.5 \dots 10.5 \text{ В}$; $I_{F1} < 3 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BG5	MMBZ5242ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 20 \text{ мА}) < 11.4 \dots 12.6 \text{ В}$; $I_{F1} < 1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BG6	MMBZ5243ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 9.5 \text{ мА}) < 12.35 \dots 13.65 \text{ В}$; $I_{F1} < 0.5 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BG7	MMBZ5244ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 8.5 \text{ мА}) < 13.30 \dots 14.70 \text{ В}$; $I_{F1} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BG8	MMBZ5245ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 8.5 \text{ мА}) < 14.25 \dots 15.75 \text{ В}$; $I_{F1} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BG9	MMBZ5246ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 7.8 \text{ мА}) < 15.2 \dots 16.8 \text{ В}$; $I_{F1} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BGp	BCX71G	PHIL	pnip	$V_{CE0} > 45 \text{ В}$; $I_C < 200 \text{ мА}$; $P_D < 250 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 120$; 220 ; $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BGs	BCX71G	SIEM	pnip	$V_{CE0} > 45 \text{ В}$; $I_C < 100 \text{ мА}$; $P_D < 330 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 120$; 220 ; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BGt	BCX71G	PHIL	pnip	$V_{CE0} > 45 \text{ В}$; $I_C < 200 \text{ мА}$; $P_D < 250 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 120$; 220 ; $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BH	1SS295	TOSH	shd-2	$V_{F1} > 4 \text{ В}$; $I_C < 30 \text{ мА}$; $V_{F1}(I_C < 2 \text{ мА}) < 0.32 \text{ В}$; $I_C < 25 \text{ мкА}$	SOT346, SC59	A1-K2-K1, A2
BH	1SS350	SANYO	shd	$V_{F1} > 5 \text{ В}$; $V_{F1}(I_{F1} < 1 \text{ мА}) < 0.23 \text{ В}$; $I_{F1}(V_{F1} < 0.5 \text{ В}) < 25 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BH	BCX71H	ALLEG	pnip	$V_{CE0} > 45 \text{ В}$; $I_{CBO} < 20 \text{ нА}$; $h_{FE1} > 180$; 310 ; $V_{CE(sat)} < 0.25 \text{ В}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BH	BCX71H	CDIL	pnip	$V_{CE0} > 45 \text{ В}$; $I_C < 200 \text{ мА}$; $P_D < 250 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 180$; 310 ; $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BH	BCX71H	SAMS	pnip	$V_{CE0} > 45 \text{ В}$; $I_C < 100 \text{ мА}$; $P_D < 350 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 140$; 310	SOT23, SOD23	B-E-C
BH	BCX71H	ZETEX	pnip	$V_{CE0} > 45 \text{ В}$; $I_C < 200 \text{ мА}$; $P_D < 330 \text{ мВт}$; $h_{FE1} > 180$; 310 ; $f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BH2	MMBZ5248ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 7.0 \text{ мА}) < 17.1 \dots 18.9 \text{ В}$; $I_{F1} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BH4	MMBZ5250ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 6.2 \text{ мА}) < 19.0 \dots 21.0 \text{ В}$; $I_{F1} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BH6	MMBZ5252ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 5.2 \text{ мА}) < 22.8 \dots 25.2 \text{ В}$; $I_{F1} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BH7	MMBZ5253ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 5.0 \text{ мА}) < 23.75 \dots 26.25 \text{ В}$; $I_{F1} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BH8	MMBZ5254ELT1	ON	dz	$V_{F1}(I_{F1} < 5.0 \text{ мА}) < 25.65 \dots 28.35 \text{ В}$; $I_{F1} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоназвание	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
BH9	MMBZ5255ELT1	ON	dz	$V_{(I_{T1})} = 4.5 \text{ mA}$; 26.6...29.4 В; $I_{R1} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BHM	2SC4699KM	ROHM	npn	$V_{CEB} = 25 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 39...82$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
BHM	2SC4700M	ROHM	npn	$V_{CEB} = 25 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 39...82$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
BHN	2SC4699KN	ROHM	npn	$V_{CEB} = 25 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 56...120$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
BHN	2SC4700N	ROHM	npn	$V_{CEB} = 25 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 56...120$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
BHP	2SC4699KP	ROHM	npn	$V_{CEB} = 25 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 82...180$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
BHP	2SC4700P	ROHM	npn	$V_{CEB} = 25 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 82...180$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
BHP	BCX71H	PHIL	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 250 \text{ мВт}$; $h_{21} = 180...310$; $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BHS	BCX71H	SIEM	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_C = 100 \text{ mA}$; $P_D = 330 \text{ мВт}$; $h_{21} = 180...310$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BHt	BCX71H	PHIL	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 250 \text{ мВт}$; $h_{21} = 180...310$; $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BJ	BCX71J	ALLEG	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_{CB} < 20 \text{ нА}$; $h_{21} = 250...460$; $V_{CE(sat)} < 0.25 \text{ В}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BJ	BCX71J	CDIL	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 250 \text{ мВт}$; $h_{21} = 250...460$; $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BJ	BCX71J	SAMS	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_C = 100 \text{ mA}$; $P_D = 350 \text{ мВт}$; $h_{21} = 250...460$	SOT23, SOD23	B-E-C
BJ	BCX71J	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 330 \text{ мВт}$; $h_{21} = 250...460$; $f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BJ1	MMBZ5256ELT1	ON	dz	$V_{(I_{T1})} = 4.2 \text{ mA}$; 28.5...31.5 В; $I_{R1} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BJ2	MMBZ5257ELT1	ON	dz	$V_{(I_{T1})} = 3.8 \text{ mA}$; 31.35...34.65 В; $I_{R1} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BJ3	MMBZ5258ELT1	ON	dz	$V_{(I_{T1})} = 3.4 \text{ mA}$; 34.2...37.8 В; $I_{R1} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BJ7	MMBZ5262ELT1	ON	dz	$V_{(I_{T1})} = 2.5 \text{ mA}$; 48.45...53.55 В; $I_{R1} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BJ8	MMBZ5263ELT1	ON	dz	$V_{(I_{T1})} = 2.2 \text{ mA}$; 53.20...58.80 В; $I_{R1} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BJp	BCX71J	PHIL	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 250 \text{ мВт}$; $h_{21} = 250...460$; $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BJs	BCX71J	SIEM	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_C = 100 \text{ mA}$; $P_D = 330 \text{ мВт}$; $h_{21} = 250...460$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BJt	BCX71J	PHIL	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 250 \text{ мВт}$; $h_{21} = 250...460$; $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BJJ	2SD2226KU	ROHM	npn	$V_{CEB} = 60 \text{ В}$; $I_C = 150 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 560...1200$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
BJU	2SD2351U	ROHM	npn	$V_{CEB} = 60 \text{ В}$; $I_C = 150 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 560...1200$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
BJV	2SD2226KV	ROHM	npn	$V_{CEB} = 60 \text{ В}$; $I_C = 150 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 820...1800$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
BJW	2SD2351W	ROHM	npn	$V_{CEB} = 60 \text{ В}$; $I_C = 150 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 820...1800$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
BJX	2SD2226KW	ROHM	npn	$V_{CEB} = 60 \text{ В}$; $I_C = 150 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 1200...2700$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
BJW	2SD2351W	ROHM	npn	$V_{CEB} = 60 \text{ В}$; $I_C = 150 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 1200...2700$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
BK	BCX71K	ALLEG	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_{CB} < 20 \text{ нА}$; $h_{21} = 380...630$; $V_{CE(sat)} < 0.25 \text{ В}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BK	BCX71K	CDIL	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 250 \text{ мВт}$; $h_{21} = 380...630$; $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BK	BCX71K	SAMS	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_C = 100 \text{ mA}$; $P_D = 350 \text{ мВт}$; $h_{21} = 380...630$	SOT23, SOD23	B-E-C
BK	BCX71K	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 330 \text{ мВт}$; $h_{21} = 380...630$; $f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BK1	MMBZ5265ELT1	ON	dz	$V_{(I_{T1})} = 2 \text{ mA}$; 58.90...65.10 В; $I_{R1} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
BKp	BCX71K	PHIL	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 250 \text{ мВт}$; $h_{21} = 380...630$; $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BKs	BCX71K	SIEM	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_C = 100 \text{ mA}$; $P_D = 330 \text{ мВт}$; $h_{21} = 380...630$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BKt	BCX71K	PHIL	npn	$V_{CEB} = 45 \text{ В}$; $I_C = 200 \text{ mA}$; $P_D = 250 \text{ мВт}$; $h_{21} = 380...630$; $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BLL	2SC4771KL	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 27...56$; $f_T = 600 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
BLL	2SC4772L	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 27...56$; $f_T = 600 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
BLL	2SC4771KM	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 39...82$; $f_T = 600 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
BLL	2SC4772M	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 39...82$; $f_T = 600 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
BLN	2SC4771KN	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 56...120$; $f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
BLN	2SC4772N	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 56...120$; $f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
BLP	2SC4771KP	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 82...180$; $f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
BLP	2SC4772P	ROHM	npn	$V_{CEB} = 30 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 82...180$; $f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
BM	BSS63L	MOT	npn	$V_{CEB} = 100 \text{ В}$; $I_C = 800 \text{ mA}$; $P_D = 330 \text{ мВт}$; $h_{21} > 30$; $f_T = 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BMp	BSS63	PHIL	npn	$V_{CEB} = 110 \text{ В}$; $I_C = 100 \text{ mA}$; $P_D = 250 \text{ мВт}$; $h_{21} > 30$; $f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
BMQ	2SC4713KQ	ROHM	npn	$V_{CEB} = 12 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 120...270$; $f_T = 800 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
BMQ	2SC4774Q	ROHM	npn	$V_{CEB} = 12 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 120...270$; $f_T = 800 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
BMR	2SC4713KR	ROHM	npn	$V_{CEB} = 12 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 180...390$; $f_T = 800 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
BMR	2SC4774R	ROHM	npn	$V_{CEB} = 12 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 180...390$; $f_T = 800 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
BMS	2SC4713KS	ROHM	npn	$V_{CEB} = 12 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 270...560$; $f_T = 800 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
BMS	2SC4774S	ROHM	npn	$V_{CEB} = 12 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} = 270...560$; $f_T = 800 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	СИМ	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
BMs	BSS63	npn	V _{CE0} = 100 В; I _C = 800 мА; P ₀ = 330 мВт; h ₂₁ > 30; f _T = 150 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
BmT	BSS63	PHIL npn	V _{CE0} = 110 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 250 мВт; h ₂₁ > 30; f _T > 50 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
BN	2SK3290	REN nMOS	V _{DS} = 30 В; I _D = 500 мА; P ₀ = 400 мВт; R _{DS(on)} < 1.25 Ом	SOT23, SOD23	G-S-D	
BnS	BCW61AR	SIEM npn	V _{CE0} = 32 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 330 мВт; h ₂₁ = 380...630; f _T = 250 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
BO	BCW61AR	PHIL npn	V _{CE0} = 32 В; I _C = 200 мА; P ₀ = 250 мВт; h ₂₁ = 120...220; f _T > 100 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
BP	2SJ574	REN pMOS	V _{DS} = 30 В; I _D = 300 мА; P ₀ = 400 мВт; R _{DS(on)} < 3.1 Ом	SOT23, SOD23	G-S-D	
BQ	2PB709AQ	PHIL npn	V _{CE0} = 45 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 250 мВт; h ₂₁ = 160...260; f _T > 70 МГц	SOT346, SC59	B-E-C	
BQ	2SC2412KQ	ROHM npn	V _{CE0} = 50 В; I _C = 150 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 120...270; f _T > 180 МГц	SOT346, SC59	B-E-C	
BQ	2SC2412KQLT	LRC npn	V _{CE0} = 60 В; I _C = 150 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 120...270; f _T = 180 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
BQ	2SC4081Q	ROHM npn	V _{CE0} = 50 В; I _C = 150 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 120...270; f _T > 180 МГц	SOT323, SC70	B-E-C	
BQ	2SC4617	ROHM npn	V _{CE0} = 50 В; I _C = 150 мА; P ₀ = 150 мВт; h ₂₁ = 120...270; f _T > 180 МГц	SOT416, SC75A	B-E-C	
BQ	2SC5658Q	ROHM npn	V _{CE0} = 60 В; I _C = 150 мА; P ₀ = 150 мВт; h ₂₁ = 120...270; f _T > 180 МГц	VMT3, VMD3	B-E-C	
BR	2PB709AR	PHIL npn	V _{CE0} = 45 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 250 мВт; h ₂₁ = 290...460; f _T = 80 МГц	SOT346, SC59	B-E-C	
BR	2SC2412KR	ROHM npn	V _{CE0} = 50 В; I _C = 150 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 180...390; f _T > 180 МГц	SOT346, SC59	B-E-C	
BR	2SC2412KRLT	LRC npn	V _{CE0} = 60 В; I _C = 150 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 180...390; f _T = 180 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
BR	2SC4081R	ROHM npn	V _{CE0} = 50 В; I _C = 150 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 180...390; f _T > 180 МГц	SOT323, SC70	B-E-C	
BR	2SC4617	ROHM npn	V _{CE0} = 50 В; I _C = 150 мА; P ₀ = 150 мВт; h ₂₁ = 180...390; f _T > 180 МГц	SOT416, SC75A	B-E-C	
BR	2SC5658R	ROHM npn	V _{CE0} = 60 В; I _C = 150 мА; P ₀ = 150 мВт; h ₂₁ = 180...390; f _T > 180 МГц	VMT3, VMD3	B-E-C	
BR	BCW60DR	PHIL npn	V _{CE0} = 32 В; I _C = 200 мА; P ₀ = 330 мВт; h ₂₁ = 380...630; f _T > 250 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
BR	MSB1218ART1	MOT npn	V _{CE0} = 45 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 150 мВт; h ₂₁ = 210...340	SOT323, SC70	B-E-C	
BS	2PB709AS	PHIL npn	V _{CE0} = 45 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 250 мВт; h ₂₁ = 160...260; f _T > 60 МГц	SOT346, SC59	B-E-C	
BS	2SC2412KS	ROHM npn	V _{CE0} = 50 В; I _C = 150 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 270...560; f _T > 180 МГц	SOT346, SC59	B-E-C	
BS	2SC2412KSLT	LRC npn	V _{CE0} = 60 В; I _C = 150 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 270...560; f _T = 180 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
BS	2SC4081S	ROHM npn	V _{CE0} = 50 В; I _C = 150 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 270...560; f _T > 180 МГц	SOT323, SC70	B-E-C	
BS	2SC4617	ROHM npn	V _{CE0} = 50 В; I _C = 150 мА; P ₀ = 150 мВт; h ₂₁ = 270...560; f _T > 180 МГц	SOT416, SC75A	B-E-C	
BS	2SC5658S	ROHM npn	V _{CE0} = 60 В; I _C = 150 мА; P ₀ = 150 мВт; h ₂₁ = 270...560; f _T > 180 МГц	VMT3, VMD3	B-E-C	
BS	MSB1218AST1	MOT npn	V _{CE0} = 45 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 150 мВт; h ₂₁ = 290...460	SOT323, SC70	B-E-C	
BSA	BC848AU	AUK npn	V _{CE0} = 30 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 110...220; f _T = 150 МГц	SOT323, SC70	B-E-C	
BSA	BC848AUF	AUK npn	V _{CE0} = 30 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 110...220; f _T = 150 МГц	SOT323, SC70	B-E-C	
BSB	BC848BU	AUK npn	V _{CE0} = 30 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 200...450; f _T = 150 МГц	SOT323, SC70	B-E-C	
BSB	BC848BUF	AUK npn	V _{CE0} = 30 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 200...450; f _T = 150 МГц	SOT323, SC70	B-E-C	
BSC	BC848CU	AUK npn	V _{CE0} = 30 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 420...800; f _T = 150 МГц	SOT323, SC70	B-E-C	
BSC	BC848CUF	AUK npn	V _{CE0} = 30 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 420...800; f _T = 150 МГц	SOT323, SC70	B-E-C	
BV	1SV247	SANYO npn	V _{DS} > 50 В; I _D < 50 мА; V _{CE(sat)} (50 мА) = 0.95 В; I _B < 0.1 мкА	SOT323, SC70	A-n.c.-K	
C	IRLML6302	IR pMOS	HEXFET; V _{DS} = 20 В; I _D = 0.62 А; P ₀ = 540 мВт; R _{DS(on)} < 0.9 Ом	SOT23, SOD23	G-S-D	
C0	HSMS2820	HP shd	V _{DS} > 15 В; V _{CE(sat)} (-30 мА) < 0.7 В; I _B (V _{CE(sat)} = 1 В) < 100 нА; C ₀ < 1.0 нФ	SOT23, SOD23	A-n.c.-K	
C0	HSMS2822B	HP shd	V _{DS} > 15 В; V _{CE(sat)} (-30 мА) < 0.7 В; I _B (V _{CE(sat)} = 1 В) < 100 нА; C ₀ < 1.0 нФ; R ₀ = 12 Ом	SOT23, SC70	A-n.c.-K	
C1	BCW29	ALLEG npn	V _{CE0} = 30 В; I _C < 100 нА; h ₂₁ = 120...260; V _{CE(sat)} < 0.3 В	SOT23, SOD23	B-E-C	
C1	BCW29	CDIL npn	V _{CE0} = 30 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 330 мВт; h ₂₁ = 120...260; f _T > 150 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
C1	BCW29	SAMS npn	V _{CE0} = 30 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 350 мВт; h ₂₁ = 120...260	SOT23, SOD23	B-E-C	
C1	BCW29	ZETEX npn	V _{CE0} = 30 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 330 мВт; h ₂₁ = 120...260; f _T > 150 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
C1	HSMS2821	HP shd	V _{DS} > 15 В; V _{CE(sat)} (-30 мА) < 0.7 В; I _B (V _{CE(sat)} = 1 В) < 100 нА; C ₀ < 1.0 нФ	SOT23, SOD23	n.c.-A-K	
C1	MMBZ5221BT	DIODS dz	V _{RRM} = 20 мА; 2.28...2.52 В; I _S < 100 мкА	SOT523	A-n.c.-K	
C1	STT111	SIL nFET	V _{DS} = 35 В; P ₀ = 350 мВт; I _{DM} > 20 мА; R _{DS(on)} < 30 Ом	SOT23, SOD23	D-S-G	
CI A	CMPT3904	CSI npn	V _{CE0} = 60 В; I _C = 200 мА; P ₀ = 350 мВт; h ₂₁ = 100...300; f _T > 300 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
CI D	CMPTA42	CSI npn	V _{CE0} = 300 В; I _C = 500 мА; P ₀ = 350 мВт; h ₂₁ > 40; f _T = 50 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
CI G	CMPTA06	CSI npn	V _{CE0} = 80 В; I _C = 500 мА; P ₀ = 350 мВт; h ₂₁ > 50; f _T > 100 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
C1G	KSA1623	SAMS npn	V _{CE0} = 60 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 200...400; f _T > 250 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
C1J	CMPT2369	CSI npn	V _{CE0} = 40 В; I _C = 500 мА; P ₀ = 350 мВт; h ₂₁ = 40...120; f _T > 500 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
C1K	CMPT6428	CSI npn	V _{CE0} = 60 В; I _C = 200 мА; P ₀ = 350 мВт; h ₂₁ = 250...650; f _T = 100...700 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
C1L	CMPT6429	CSI npn	V _{CE0} = 55 В; I _C = 200 мА; P ₀ = 350 мВт; h ₂₁ = 500...1250; f _T = 100...700 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	
C1L	KSA1623	SAMS npn	V _{CE0} = 60 В; I _C = 100 мА; P ₀ = 200 мВт; h ₂₁ = 300...600; f _T > 250 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C	

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
C1M	CMPTA13	CSI	npn	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 5000; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
S1M	CMPTA14	CSI	npn	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 10000; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C1O	KSA1623	SAMS	npn	$V_{CEB} > 60 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 90...180; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C1P	BCW29	PHIL	npn	$V_{CEB} > 32 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 120...260; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C1P	CMPT2222A	CSI	npn	$V_{CEB} > 75 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 35; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-cmp-C
C1Q	CMPT5088	CSI	npn	$V_{CEB} > 35 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 300...900; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C1R	CMPT5089	CSI	npn	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 400...1200; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C1t	BCW29	PHIL	npn	$V_{CEB} > 32 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 120...260; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C1U	CMPT2484	CSI	npn	$V_{CEB} > 60 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 250...800$	SOT23,SOD23	B-E-C
C1B	CMPT6427	CSI	npn	$V_{CEB} > 40 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 10...100 \text{ к}; f_T > 130 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C1X	CMPT1930	CSI	npn	$V_{CEB} > 45 \text{ В}; I_C < 30 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 30 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C1Y	KSA1623	SAMS	npn	$V_{CEB} > 60 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 135...270; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C1Z	CMPT6517	CSI	npn	$V_{CEB} > 350 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 20...200; f_T > 40...200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2	BCW30	ALLEG	npn	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_{CB} < 100 \text{ мА}; h_{21} > 215...500; V_{CE(sat)} < 0.3 \text{ В}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2	BCW30	CDIL	npn	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 215...500; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2	BCW30	ZETEX	npn	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 215...500; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2	HSMS2822	HP	shd-2	$V_{BR} > 15 \text{ В}; V_{F(I_F=30 \text{ мА})} < 0.7 \text{ В}; I_{B(I_F=1 \text{ В})} < 100 \text{ нА}; C_C < 1.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1A2
C2	HSMS282C	HP	shd-2	$V_{BR} > 15 \text{ В}; V_{F(I_F=30 \text{ мА})} < 0.7 \text{ В}; I_{B(I_F=1 \text{ В})} < 100 \text{ нА}; C_C < 1.0 \text{ нФ}; P_D < 12 \text{ Ом}$	SOT23,SC70	A1-K2-K1A2
C2	SST112	SIL	nFET	$V_{DS} > 35 \text{ В}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{DSS} > 5 \text{ мА}; R_{DS(on)} < 50 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	D-S-G
C29	CMPTA29	CSI	npn	$V_{CEB} > 100 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 10000; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2A	CMPT3906	CSI	npn	$V_{CEB} > 40 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2A	ZDC833A	ZETEX	var-2	$V_A < 25 \text{ В}; C_{2B} > 29.7...33.6 \text{ пФ}; C_{2B} @ C_{2B} > 5...6.5; Q > 200$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
C2D	CMPTA92	CSI	npn	$V_{CEB} > 300 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 25; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2F	CMPT2907A	CSI	npn	$V_{CEB} > 60 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2G	CMPTA56	CSI	npn	$V_{CEB} > 80 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2J	CMPT3640	CSI	npn	$V_{CEB} > 12 \text{ В}; I_C < 80 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 30...120; f_T > 500 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2L	CMPT5401	CSI	npn	$V_{CEB} > 160 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 60...240; f_T > 100...300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2p	BCW30	PHIL	npn	$V_{CEB} > 32 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 215...500; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2P	CMPT5086	CSI	npn	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 150...500; f_T > 40 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2Q	CMPT5087	CSI	npn	$V_{CEB} > 50 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 250...800; f_T > 40 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2R	CMPT3646	CSI	npn	$V_{CEB} > 40 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 30...120; f_T > 350 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2t	BCW30	PHIL	npn	$V_{CEB} > 32 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 215...500; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2T	CMPT4403	CSI	npn	$V_{CEB} > 40 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2U	CMPTA63	CSI	npn	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 10000; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2v	CMPTA64	CSI	npn	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 20000; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2w	CMPT8599	CSI	npn	$V_{CEB} > 80 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2X	CMPT4401	CSI	npn	$V_{CEB} > 60 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C2Z	CMPT6520	CSI	npn	$V_{CEB} > 350 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 20...200; f_T > 40...200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C3	1PS302	PHIL	fd-2	$V_A < 80 \text{ В}; I_F < 200 \text{ мА}; V_{F(I_F=50 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; I_{RR} < 4 \text{ нс}$	SOT323,SC70	A1-K2-K1A2
C3	1SS226	TOSH	di-2	$V_A < 80 \text{ В}; I_F < 100 \text{ мА}; V_{F(I_F=100 \text{ мА})} < 1.2 \text{ В}; I_B < 0.5 \text{ мА}; I_{RR} < 4 \text{ нс}$	SOT346,SC59	A1-K2-K1A2
C3	1SS302	TOSH	di-2	$V_A < 80 \text{ В}; I_F < 100 \text{ мА}; V_{F(I_F=100 \text{ мА})} < 1.2 \text{ В}; I_{RR} < 4 \text{ нс}$	SOT323,SC70	A1-K2-K1A2
C3	1SS362	TOSH	di-2	$V_A < 80 \text{ В}; I_F < 80 \text{ мА}; V_{F(I_F=80 \text{ мА})} < 1.2 \text{ В}; I_B < 0.5 \text{ мА}; I_{RR} < 4 \text{ нс}$	SOT416,SC75A	A1-K2-K1A2
C3	HSMS2823	HP	shd-2	$V_{BR} > 15 \text{ В}; V_{F(I_F=30 \text{ мА})} < 0.7 \text{ В}; I_{B(I_F=1 \text{ В})} < 100 \text{ нА}; C_C < 1.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1A2
C3	HSMS282E	HP	shd-2	$V_{BR} > 15 \text{ В}; V_{F(I_F=30 \text{ мА})} < 0.7 \text{ В}; I_{B(I_F=1 \text{ В})} < 100 \text{ нА}; C_C < 1.0 \text{ нФ}; P_D < 12 \text{ Ом}$	SOT323,SC70	K1-K2-A2,A1
C3	KST4126	SAMS	npn	$V_{CEB} > 25 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 120...360; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C3	MMBZ5223BT	DIODS	dz	$V_{F(I_{F1}=20 \text{ мА})} < 2.57...2.84 \text{ В}; I_B < 75 \text{ мкА}$	SOT523	A-n.c.-K
C3	SST113	SIL	nFET	$V_{DS} > 35 \text{ В}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{DSS} > 2 \text{ мА}; R_{DS(on)} < 100 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	D-S-G
C38	SST5638	SIL	nFET	$V_{DS} > 30 \text{ В}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{DSS} > 50 \text{ мА}; R_{DS(on)} < 30 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	D-S-G
C39	SST5639	SIL	nFET	$V_{DS} > 30 \text{ В}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{DSS} > 25 \text{ мА}; R_{DS(on)} < 60 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	D-S-G
C3A	CMPT3019	CSI	npn	$V_{CEB} > 120 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 100...300; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C3B	CMPT1918	CSI	npn	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 20; f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C3E	CMPTH10	CSI	npn	$V_{CEB} > 30 \text{ В}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 60; f_T > 650 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типонаимал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
C3Z	CMPTA44	CSI	npn	$V_{CBO} > 450$ В; $I_C < 300$ мА; $P_D < 350$ мВт; $h_{21} > 50$; $t_{21} > 20$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
C4	BCW29R	PHIL	npn	$V_{CBO} > 32$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 350$ мВт; $h_{21} > 120$; $t_{21} > 260$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
C4	BCW29R	ZETEX	npn	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} > 120$; $t_{21} > 260$; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	E-B-C
C4	HSMS2824	HP	shd-2	$V_{BE} > 15$ В; $V_{CE} < 30$ мА; $I_C < 0.7$ В; $I_B < 1$ В; $I_C < 100$ нА; $C_{D0} < 1.0$ пФ	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
C4	HSMS2824	HP	shd-2	$V_{BE} > 15$ В; $V_{CE} < 30$ мА; $I_C < 0.7$ В; $I_B < 1$ В; $I_C < 100$ нА; $C_T < 1.0$ пФ; $P_D < 12$ Ом	SOT23, SC70	A1-A2-K2, K1
C40	SST5640	SIL	nFET	$V_{DS} < 30$ В; $P_D < 350$ мВт; $I_{DSS} > 5$ мА; $R_{DS(on)} < 100$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G
C41	SST4091	SIL	nFET	$V_{DS} < 35$ В; $P_D < 350$ мВт; $I_{DSS} > 30$ мА; $R_{DS(on)} < 30$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G
C42	SST4092	SIL	nFET	$V_{DS} < 35$ В; $P_D < 350$ мВт; $I_{DSS} > 30$ мА; $R_{DS(on)} < 50$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G
C43	SST4093	SIL	nFET	$V_{DS} < 35$ В; $P_D < 350$ мВт; $I_{DSS} > 30$ мА; $R_{DS(on)} < 80$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G
C4A	CMPT4033	CSI	npn	$V_{CBO} > 80$ В; $I_C < 500$ мА; $P_D < 350$ мВт; $h_{21} > 100$; $t_{21} > 300$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
C5	BCW30R	PHIL	npn	$V_{CBO} > 20$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 350$ мВт; $h_{21} > 215$; $t_{21} > 500$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	E-B-C
C5	BCW30R	ZETEX	npn	$V_{CBO} > 30$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 330$ мВт; $h_{21} > 215$; $t_{21} > 500$; $f_T > 150$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
C5	MMBA811C5	MOT	npn	$V_{CBO} > 50$ В; $I_C < 50$ мА; $P_D < 350$ мВт; $h_{21} > 135$; $t_{21} > 270$	SOT23, SOD23	B-E-C
C5	MMBZ52258T	DIODS	dz	$V_{F1}(I_T > 20$ мА) > 2.85 ... 3.15 В; $I_R < 50$ мкА	SOT523	A-n.c.-K
C56	SST4856	SIL	nFET	$V_{DS} < 40$ В; $P_D < 350$ мВт; $I_{DSS} > 50$ мА; $R_{DS(on)} < 25$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G
C57	SST4857	SIL	nFET	$V_{DS} < 40$ В; $P_D < 350$ мВт; $I_{DSS} > 20$ мА; $R_{DS(on)} < 40$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G
C58	SST4858	SIL	nFET	$V_{DS} < 40$ В; $P_D < 350$ мВт; $I_{DSS} > 8$ мА; $R_{DS(on)} < 60$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G
C59	SST4859	SIL	nFET	$V_{DS} < 30$ В; $P_D < 350$ мВт; $I_{DSS} > 50$ мА; $R_{DS(on)} < 25$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G
C5A	ZDCR34A	ZETEX	var-2	$V_B < 25$ В; $I_C < 200$ мА; $I_B < 0.02$ мкА; $C_{2B} < 42$... 51.7 нФ; $C_{2B} / C_{20B} > 5.0$... 6.5	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
C5C	CMPT7000	CSI	fid-2	$I_C < 200$ мА; $V_{BE} > 100$ В; $V_{CE} < 100$ мА; $t_{21} > 0.75$... 1.10 В; $I_B < 300$ нА; $I_{SS} < 4.0$ нС; $C_T < 1.5$ нФ	SOT23, SOD23	A2-K1-K2, A1
C5D	CMPT914	CSI	fid	$I_C < 250$ мА; $V_B > 75$ В; $V_{CE} < 10$ мА; $I_B < 25$ нА; $I_{SS} < 4.0$ нС; $C_T < 4.0$ пФ	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
C6	MMBA811C6	SAMS	npn	$V_{CBO} > 50$ В; $I_C < 50$ мА; $P_D < 350$ мВт; $h_{21} > 200$; $t_{21} > 400$	SOT23, SOD23	B-E-C
C6	MMBA811C6	MOT	npn	$V_{CBO} > 50$ В; $I_C < 50$ мА; $P_D < 300$ мВт; $h_{21} > 200$; $t_{21} > 400$	SOT23, SOD23	B-E-C
C60	SST4860	SIL	nFET	$V_{DS} < 30$ В; $P_D < 350$ мВт; $I_{DSS} > 20$ мА; $R_{DS(on)} < 40$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G
C61	SST4861	SIL	nFET	$V_{DS} < 30$ В; $P_D < 350$ мВт; $I_{DSS} > 8$ мА; $R_{DS(on)} < 60$ Ом	SOT23, SOD23	D-S-G
C7	MMBA811C7	SAMS	npn	$V_{CBO} > 50$ В; $I_C < 50$ мА; $P_D < 350$ мВт; $h_{21} > 300$; $t_{21} > 600$	SOT23, SOD23	B-E-C
C7	MMBA811C7	MOT	npn	$V_{CBO} > 50$ В; $I_C < 50$ мА; $P_D < 300$ мВт; $h_{21} > 300$; $t_{21} > 600$	SOT23, SOD23	B-E-C
C77	BCF29R	PHIL	npn	$V_{CBO} > 32$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 350$ мВт; $h_{21} > 120$; $t_{21} > 260$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	E-B-C
C7H	CMPT5179	CSI	npn	$V_{CBO} > 20$ В; $I_C < 50$ мА; $P_D < 350$ мВт; $h_{21} > 25$; $f_T > 900$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
C7P	BCF29	PHIL	npn	$V_{CBO} > 32$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 250$ мВт; $h_{21} > 120$; $t_{21} > 260$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
C8	BCF30	SGS	npn	$V_{CBO} > 32$ В; $I_C < 100$ мА; $P_D < 250$ мВт; $h_{21} > 215$; $t_{21} > 500$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
C8	MMBA811C8	SAMS	npn	$V_{CBO} > 50$ В; $I_C < 50$ мА; $P_D < 350$ мВт; $h_{21} > 450$; $t_{21} > 900$	SOT23, SOD23	B-E-C
C8	MMBA811C8	MOT	npn	$V_{CBO} > 50$ В; $I_C < 50$ мА; $P_D < 300$ мВт; $h_{21} > 450$; $t_{21} > 900$	SOT23, SOD23	B-E-C
C8A	CMPT5226B	CSI	dz	$V_{F1}(I_T > 20$ мА) > 3.135 ... 3.465 В; $I_B < 1.0$ В; $I_C < 25$ мкА; $Z_{T1}(I_T > 20$ мА) < 28 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
C8B	CMPT5227B	CSI	dz	$V_{F1}(I_T > 20$ мА) > 3.42 ... 3.78 В; $I_B < 1.0$ В; $I_C < 15$ мкА; $Z_{T1}(I_T > 20$ мА) < 24 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
C8C	CMPT5228B	CSI	dz	$V_{F1}(I_T > 20$ мА) > 3.705 ... 4.095 В; $I_B < 1.0$ В; $I_C < 10$ мкА; $Z_{T1}(I_T > 20$ мА) < 23 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
C8D	CMPT5229B	CSI	dz	$V_{F1}(I_T > 20$ мА) > 4.085 ... 4.515 В; $I_B < 1.0$ В; $I_C < 5.0$ мкА; $Z_{T1}(I_T > 20$ мА) < 22 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
C8E	CMPT5230B	CSI	dz	$V_{F1}(I_T > 20$ мА) > 4.465 ... 4.935 В; $I_B < 2.0$ В; $I_C < 5.0$ мкА; $Z_{T1}(I_T > 20$ мА) < 19 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
C8F	CMPT5231B	CSI	dz	$V_{F1}(I_T > 20$ мА) > 4.845 ... 5.355 В; $I_B < 2.0$ В; $I_C < 5.0$ мкА; $Z_{T1}(I_T > 20$ мА) < 17 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
C8G	CMPT5232B	CSI	dz	$V_{F1}(I_T > 20$ мА) > 5.320 ... 5.880 В; $I_B < 3.0$ В; $I_C < 5.0$ мкА; $Z_{T1}(I_T > 20$ мА) < 11 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
C8H	CMPT5233B	CSI	dz	$V_{F1}(I_T > 20$ мА) > 5.700 ... 6.300 В; $I_B < 3.5$ В; $I_C < 5.0$ мкА; $Z_{T1}(I_T > 20$ мА) < 7.0 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
C8J	CMPT5234B	CSI	dz	$V_{F1}(I_T > 20$ мА) > 5.890 ... 6.510 В; $I_B < 4.0$ В; $I_C < 5.0$ мкА; $Z_{T1}(I_T > 20$ мА) < 7.0 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
C8K	CMPT5235B	CSI	dz	$V_{F1}(I_T > 20$ мА) > 6.460 ... 7.140 В; $I_B < 5.0$ В; $I_C < 3.0$ мкА; $Z_{T1}(I_T > 20$ мА) < 5.0 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
C8L	CMPT5236B	CSI	dz	$V_{F1}(I_T > 20$ мА) > 7.125 ... 7.875 В; $I_B < 6.0$ В; $I_C < 3.0$ мкА; $Z_{T1}(I_T > 20$ мА) < 6.0 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
C8M	СMPZ5237В	CSI	dz	$V_{I(HI)}=20\text{ mA}; I_{T1}=7.790...8.610\text{ B}; I_L(V_R=6.5\text{ B}) < 3.0\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{T1}=20\text{ mA}) < 8.0\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
C8N	СMPZ5238В	CSI	dz	$V_{I(HI)}=20\text{ mA}; I_{T1}=8.265...9.135\text{ B}; I_L(V_R=6.5\text{ B}) < 3.0\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{T1}=20\text{ mA}) < 8.0\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
C8p	BCF30	PHIL	pnp	$V_{CEB}=32\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; P_D=250\text{ мВт}; h_{21}=215...500; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
C8P	СMPZ5239В	CSI	dz	$V_{I(HI)}=20\text{ mA}; I_{T1}=8.645...9.555\text{ B}; I_L(V_R=6.5\text{ B}) < 3.0\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{T1}=20\text{ mA}) < 10\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
C8Q	СMPZ5240В	CSI	dz	$V_{I(HI)}=20\text{ mA}; I_{T1}=9.500...10.50\text{ B}; I_L(V_R=8.0\text{ B}) < 3.0\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{T1}=20\text{ mA}) < 17\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
C8R	СMPZ5241В	CSI	dz	$V_{I(HI)}=20\text{ mA}; I_{T1}=10.45...11.55\text{ B}; I_L(V_R=8.4\text{ B}) < 2.0\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{T1}=20\text{ mA}) < 22\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
C8S	СMPZ5242В	CSI	dz	$V_{I(HI)}=20\text{ mA}; I_{T1}=11.40...12.60\text{ B}; I_L(V_R=9.1\text{ B}) < 1.0\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{T1}=20\text{ mA}) < 30\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
C8T	СMPZ5243В	CSI	dz	$V_{I(HI)}=9.5\text{ mA}; I_{T1}=12.35...13.65\text{ B}; I_L(V_R=9.9\text{ B}) < 0.5\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{T1}=9.5\text{ mA}) < 13\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
C8U	СMPZ5244В	CSI	dz	$V_{I(HI)}=9.0\text{ mA}; I_{T1}=13.30...14.70\text{ B}; I_L(V_R=10\text{ B}) < 0.1\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{T1}=9.0\text{ mA}) < 15\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
C9	1SS307	TOSH	di	$V_R < 30\text{ B}; I_F < 100\text{ mA}; V_{F(I_F=100\text{ mA})} < 1.3\text{ B}; I_S < 0.01\text{ мкА}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
C9	BCF30R	PHIL	pnp	$V_{CEB}=32\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; P_D=350\text{ мВт}; h_{21}=215...500; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	E-B-C
CA	BCW61AR	ZETEX	pnp	$V_{CEB}=32\text{ B}; I_C=200\text{ mA}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21}=120...220; f_T > 180\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
CA	BCW61AR	PHIL	pnp	$V_{CEB}=32\text{ B}; I_C=200\text{ mA}; P_D=250\text{ мВт}; h_{21}=120...220; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	C-B-E
CA	MMBZ4691	VISH	dz	$V_{I(HI)}=50\text{ мкА}; I_{T1}=5.89...6.51\text{ B}; I_S < 10\text{ нкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
CA	RN1444A	TOSH	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ B}; I_C=300\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=200...700; f_T=30\text{ МГц}; R_T=2.2\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
CA	SST4391	SIL	nFET	$V_{DS}=40\text{ B}; P_D=350\text{ мВт}; I_{DSS} > 50\text{ mA}; g_m=6\text{ мСм}; P_{D(ESON)}=30\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	D-S-G
CA2	СMPD2836	CSI	fid-2	$I_B=200\text{ mA}; V_{RPM}=75\text{ B}; V_{F(I_F=100\text{ mA})} < 1.2\text{ B}; I_S < 100\text{ нА}; I_{RR} < 4.0\text{ нС}; C_T < 4.0\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K2-K1-A2,A1
CA6	СMPD2838	CSI	fid-2	$I_B=200\text{ mA}; V_{RPM}=75\text{ B}; V_{F(I_F=100\text{ mA})} < 1.2\text{ B}; I_S < 100\text{ нА}; I_{RR} < 4.0\text{ нС}; C_T < 4.0\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A2-A1-K2,K1
CAR	2SA1885R	ROHM	pnp	$V_{CEB}=15\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; h_{21}=180...390; f_T > 650\text{ МГц}$	SOT416,SC75A	B-E-C
CAS	2SA1885S	ROHM	pnp	$V_{CEB}=15\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; h_{21}=270...560; f_T > 650\text{ МГц}$	SOT416,SC75A	B-E-C
CB	BCW61BR	ZETEX	pnp	$V_{CEB}=32\text{ B}; I_C=200\text{ mA}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21}=180...310; f_T > 180\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
CB	BCW61BR	PHIL	pnp	$V_{CEB}=32\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21}=180...310; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	C-B-E
CB	RN1444B	TOSH	Dnnp	$V_{CEB}=50\text{ B}; I_C=300\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=350...1200; f_T=30\text{ МГц}; R_T=2.2\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
CB	SST4392	SIL	nFET	$V_{DS}=40\text{ B}; P_D=350\text{ мВт}; I_{DSS} > 25\text{ mA}; g_m=6\text{ мСм}; P_{D(ESON)}=60\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	D-S-G
CC	2SA1122B	REN	pnp	$V_{CEB}=55\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}=160...320$	SOT23,SOD23	B-E-C
CC	2SA2081C	REN	pnp	$V_{CEB}=55\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}=160...320$	SOT323,SC70	B-E-C
CC	BCW61CR	ZETEX	pnp	$V_{CEB}=32\text{ B}; I_C=200\text{ mA}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21}=250...460; f_T > 180\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
CC	BCW61CR	PHIL	pnp	$V_{CEB}=32\text{ B}; I_C=200\text{ mA}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21}=250...460; f_T > 180\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	C-B-E
CC	BF554	SIEM	npin	$V_{CEB}=20\text{ B}; I_C=30\text{ mA}; P_D=280\text{ мВт}; h_{21}=60...250; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
CC	SST4393	SIL	nFET	$V_{DS}=40\text{ B}; P_D=350\text{ мВт}; I_{DSS} > 5\text{ mA}; g_m=6\text{ мСм}; P_{D(ESON)}=100\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	D-S-G
CC	ZMDC831B	ZETEX	var-2	$V_R < 25\text{ B}; I_C < 200\text{ mA}; I_S < 0.02\text{ мкА}; C_{2B}=14.25...15.75\text{ нФ}; C_{2B}/C_{20B} < 4.5...6$	SOT323,SC70	A1-A2-K1,K2
CC10	СMPZDC27V	CSI	dz-2	$V_Z=27\text{ B}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
CC11	СMPZDC30V	CSI	dz-2	$V_Z=30\text{ B}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
CC12	СMPZDC33V	CSI	dz-2	$V_Z=33\text{ B}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
CC13	СMPZDC36V	CSI	dz-2	$V_Z=36\text{ B}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
CC14	СMPZDC39V	CSI	dz-2	$V_Z=39\text{ B}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
CC15	СMPZDC43V	CSI	dz-2	$V_Z=43\text{ B}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
CC16	СMPZDC47V	CSI	dz-2	$V_Z=47\text{ B}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
CCW3	СMPZDC2V4	CSI	dz-2	$V_Z=2.4\text{ B}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
CCW4	СMPZDC2V7	CSI	dz-2	$V_Z=2.7\text{ B}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
CCW5	СMPZDC3V0	CSI	dz-2	$V_Z=3.0\text{ B}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
CCW6	СMPZDC3V3	CSI	dz-2	$V_Z=3.3\text{ B}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
CCW7	СMPZDC3V6	CSI	dz-2	$V_Z=3.6\text{ B}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
CCW8	СMPZDC3V9	CSI	dz-2	$V_Z=3.9\text{ B}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
CCW9	CMPZDC4V3	CSI	dz-2	$V_F < 4.3 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CCY1	CMPZDC11V	CSI	dz-2	$V_F < 11 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CCY2	CMPZDC12V	CSI	dz-2	$V_F < 12 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CCY3	CMPZDC13V	CSI	dz-2	$V_F < 13 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CCY4	CMPZDC15V	CSI	dz-2	$V_F < 15 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CCY5	CMPZDC16V	CSI	dz-2	$V_F < 16 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CCY6	CMPZDC18V	CSI	dz-2	$V_F < 18 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CCY7	CMPZDC20V	CSI	dz-2	$V_F < 20 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CCY8	CMPZDC22V	CSI	dz-2	$V_F < 22 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CCY9	CMPZDC24V	CSI	dz-2	$V_F < 24 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CC21	CMPZDC4V7	CSI	dz-2	$V_F < 4.7 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CC22	CMPZDC5V1	CSI	dz-2	$V_F < 5.1 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CC23	CMPZDC5V6	CSI	dz-2	$V_F < 5.6 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CC24	CMPZDC6V2	CSI	dz-2	$V_F < 6.2 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CC25	CMPZDC6V8	CSI	dz-2	$V_F < 6.8 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CC26	CMPZDC7V5	CSI	dz-2	$V_F < 7.5 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CC27	CMPZDC8V2	CSI	dz-2	$V_F < 8.2 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CC28	CMPZDC9V1	CSI	dz-2	$V_F < 9.1 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CC29	CMPZDC10V	CSI	dz-2	$V_F < 10 \text{ В} (5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
CD	2SA1122C	REN	pnp	$V_{CE0} < 55 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 250...500$	SOT23, SOD23	B·E·C
CD	2SA2081D	REN	pnp	$V_{CE0} < 55 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 250...500$	SOT323, SOT370	B·E·C
CD	BCW61DR	ZETEX	pnnp	$V_{CE0} < 32 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 380...630; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CD	BCW61DR	PHIL	pnnp	$V_{CE0} < 32 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 380...630; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	C·B·E
CD	ZMOC832B	ZETEX	var-2	$V_R < 25 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; I_{G1} < 0.02 \text{ мкА}; C_{2B} < 20.9...23.1 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{2B0} = 5...6.5$	SOT323, SOT370	A1·A2·K1, K2
CDs	BSS81B	SIEM	npn	$V_{CE0} < 75 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40...120; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CE	2SA1122D	REN	pnnp	$V_{CE0} < 55 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 400...800$	SOT23, SOD23	B·E·C
CE	BSS79B	ZETEX	npnp	$V_{CE0} < 75 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40...120; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CEs	BSS79B	SIEM	npnp	$V_{CE0} < 75 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40...120; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CF	BSS79C	ZETEX	npnp	$V_{CE0} < 75 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CF	MMB24681	VISH	dz	$V_F (I_{ZF} < 50 \text{ мкА}) < 2.28...2.52 \text{ В}; I_S < 2 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A·n.c.·K
CFs	BSS79C	SIEM	npnp	$V_{CE0} < 75 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CG	2SA1587G	TOSH	pnnp	$V_{CE0} < 120 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 100 \text{ мВт}; h_{FE1} > 200...400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323, SOT370	B·E·C
CG	BCX71GR	ZETEX	pnnp	$V_{CE0} < 45 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 120...220; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CG	BCX71GR	PHIL	pnnp	$V_{CE0} < 45 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 120...220; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	C·B·E
CG	BRA124ECM	REN	Dnpn	$V_{CE0} < 50 \text{ В}; I_{C_{TOT}} < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 56; 22 \text{ к} / 22 \text{ к}$	SOT323, SOT370	B·E·C
CG	BRA124EMP	REN	Dnpn	$V_{CE0} < 50 \text{ В}; I_{C_{TOT}} < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 56; 22 \text{ к} / 22 \text{ к}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CGs	BSS81C	SIEM	npnp	$V_{CE0} < 75 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CH	1HS351	SANYO	shd-2	$V_R > 5 \text{ В}; V_F (I_F < 1 \text{ мА}) < 0.23 \text{ В}; I_H (V_R < 0.5 \text{ В}) < 25 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A1·K2·K1, A2
CH	BSS80B	ZETEX	pnnp	$V_{CE0} < 60 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40...120; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CH	BSS82BL	MOT	pnnp	$V_{CE0} < 60 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40...120; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CH	MMB24682	VISH	dz	$V_F (I_{ZF} < 50 \text{ мкА}) < 2.57...2.84 \text{ В}; I_S < 1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A·n.c.·K
CHA	2SC4667A	TOSH	npnp	$V_{CE0} < 15 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 100 \text{ мВт}; h_{FE1} > 600...1800; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323, SOT370	B·E·C
CHB	2SC4667B	TOSH	npnp	$V_{CE0} < 15 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 100 \text{ мВт}; h_{FE1} > 1200...3600; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323, SOT370	B·E·C
CHs	BSS80B	SIEM	pnnp	$V_{CE0} < 60 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40...120; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CJ	BSS80C	ZETEX	pnnp	$V_{CE0} < 60 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CJ	MMB24683	VISH	dz	$V_F (I_{ZF} < 50 \text{ мкА}) < 2.85...3.15 \text{ В}; I_S < 0.8 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A·n.c.·K
CJs	BSS80C	SIEM	pnnp	$V_{CE0} < 60 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CK	BCX71JR	PHIL	pnnp	$V_{CE0} < 45 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 250...460; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	C·B·E
CK	BCX71KR	ZETEX	pnnp	$V_{CE0} < 45 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 380...630; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CK	MMB24684	VISH	dz	$V_F (I_{ZF} < 50 \text{ мкА}) < 3.14...3.47 \text{ В}; I_S < 7.5 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A·n.c.·K
CKB	CMPTR8099	CSI	npn	$V_{CE0} < 80 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...300; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B·E·C
CL	2SA1587B	TOSH	pnnp	$V_{CE0} < 120 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 100 \text{ мВт}; h_{FE1} > 350...700; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323, SOT370	B·E·C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3
VMD3



SOT416 SOT323 SOT23-3
SOTS23 SOT346 SOD23-3



Код	Типономинал	З	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
CL	BSS82B	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 60 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} < 100...120; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
CLs	BSS82B	SIEM	npn	$V_{CE0} < 60 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} < 40...120; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
CM	BSS82C	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 60 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} < 100...300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
CMs	MMBZ4685	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT} < 50 \text{ мА})} < 3.42...3.78 \text{ В}; I_{R1} < 7.5 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CMs	BSS82C	SIEM	npn	$V_{CE0} < 60 \text{ В}; I_C < 800 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} < 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
CN	2SK3348	REN	nMOS	$V_{DS} < 20 \text{ В}; I_D < 100 \text{ мА}; P_D < 300 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 3.2 \text{ Ом}$	SOT323,SC70	G•S•D
CN	MMBZ4686	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT} < 50 \text{ мА})} < 3.71...4.10 \text{ В}; I_{R1} < 5 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CP	2SC2411KP	ROHM	npn	$V_{CE0} < 40 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} < 82...180; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT346,SC59	B•E•C
CP	2SC4097P	ROHM	npn	$V_{CE0} < 40 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} < 82...180; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
CP	2SJ586	REN	pMOS	$V_{DS} < 20 \text{ В}; I_D < 100 \text{ мА}; P_D < 400 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 8.5 \text{ Ом}$	SOT323,SC70	G•S•D
CP	MMBZ4687	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT} < 50 \text{ мА})} < 4.09...4.52 \text{ В}; I_{R1} < 4 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CQ	2PB1219Q	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} < 85...170; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
CQ	2SC2411KQ	ROHM	npn	$V_{CE0} < 40 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} < 120...270; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT346,SC59	B•E•C
CQ	2SC4097Q	ROHM	npn	$V_{CE0} < 40 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} < 120...270; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
CQ	MSD710Q	MOT	npn	$V_{CE0} < 25 \text{ В}; I_C < 150 \text{ мА}$	SOT346,SC59	B•E•C
CR	2PB1219R	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} < 120...240; f_T > 120 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
CR	2SC2411KR	ROHM	npn	$V_{CE0} < 40 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} < 180...390; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT346,SC59	B•E•C
CR	2SC4097R	ROHM	npn	$V_{CE0} < 40 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} < 180...390; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
CR	BCW60A	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 32 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} < 120...220; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
CR	MSD701R	MOT	npn	$V_{CE0} < 25 \text{ В}; I_C < 150 \text{ мА}$	SOT346,SC59	B•E•C
CS	2PB1219S	PHIL	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} < 170...340; f_T > 140 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
CT	MMBZ4688	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT} < 50 \text{ мА})} < 4.47...4.94 \text{ В}; I_{R1} < 10 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CU	MMBZ4689	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT} < 50 \text{ мА})} < 4.85...5.36 \text{ В}; I_{R1} < 10 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CV	1SV234	SANYO	pin-2	$V_A < 50 \text{ В}; I_F < 50 \text{ мА}; V_{F(I_F < 50 \text{ мА})} < 0.95 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	A1•K2•K1A2
CV	1SV246	SANYO	pin-2	$V_A < 50 \text{ В}; I_F < 50 \text{ мА}; V_{F(I_F < 50 \text{ мА})} < 0.95 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мА}$	SOT323,SC70	A1•K2•K1A2
CV	MMBZ4690	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT} < 50 \text{ мА})} < 5.32...5.88 \text{ В}; I_{R1} < 10 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
CWAA	MAX809LUR	MAX	mrc	$V_{TR} < 4.00 \text{ В}; V_{DD} < 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 100 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND•RST•V _{CC}
CX	MMBZ4692	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT} < 50 \text{ мА})} < 6.46...7.14 \text{ В}; I_{R1} < 10 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K
CY	MMBZ4693	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT} < 50 \text{ мА})} < 7.13...7.88 \text{ В}; I_{R1} < 10 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K
CZ	MMBZ4694	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT} < 50 \text{ мА})} < 7.79...8.61 \text{ В}; I_{R1} < 1 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K
D	IRLML5103	IR	pMOS	HEXFET; $V_{GS} < 30 \text{ В}; I_D < 0.61 \text{ А}; P_D < 540 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 1 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	G•S•D
D	MRF5771T	MOT	npn	$V_{CE0} < 20 \text{ В}; I_C < 80 \text{ мА}; P_D < 232 \text{ мВт}; h_{21} < 50...300; f_T > 7000 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
D0	HSMP3800	HP	pin	$I_F < 1 \text{ А}; V_{BR} > 100 \text{ В}; R_S < 2.0 \text{ Ом}; C_D < 0.37 \text{ нФ}; R_{th} > 1000 \text{ Ом}; R_{\theta} < 8 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•n.c.~K
D1	AZ23C2V7	VISH	dz-2	$V_Z < 2.65...2.75 \text{ В}; R_{\theta}(I_Z < 5 \text{ мА}) < 83 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1A2
D1	AZ23C2V7	VISH	dz-2	$V_Z < 2.5...2.9 \text{ В}; R_{\theta}(I_Z < 5 \text{ мА}) < 83 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1A2
D1	AZ23C2V7	TSC	dz-2	$V_Z < 2.5...2.9 \text{ В}; R_{\theta}(I_Z < 5 \text{ мА}) < 83 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1A2
D1	BCW31	ALLEG	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_{CBO} < 100 \text{ нА}; h_{21} < 110...220; V_{CE(sat)} < 0.25 \text{ В}$	SOT23,SOD23	B•E•C
D1	BCW31	CDIL	npn	$V_{CE0} < 32 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} < 110...220; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
D1	BCW31	SAMS	npn	$V_{CE0} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} < 110...220$	SOT23,SOD23	B•E•C
D1	BCW31	ZETEX	npn	$V_{CE0} < 32 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} < 110...220; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
D1	HSMP3801	HP	pin	$I_F < 1 \text{ А}; V_{BR} > 100 \text{ В}; R_S < 2.0 \text{ Ом}; C_D < 0.37 \text{ нФ}; R_{th} > 1000 \text{ Ом}; R_{\theta} < 8 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	n.c.~A•K
D10	AZ23B6V2	VISH	dz-2	$V_Z < 6.08...6.32 \text{ В}; R_{\theta}(I_Z < 5 \text{ мА}) < 10 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1A2
D10	AZ23C6V2	VISH	dz-2	$V_Z < 5.8...6.6 \text{ В}; R_{\theta}(I_Z < 5 \text{ мА}) < 10 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1A2
D10	AZ23C6V2	TSC	dz-2	$V_Z < 5.8...6.6 \text{ В}; R_{\theta}(I_Z < 5 \text{ мА}) < 10 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1A2
D10	AZ23B6V8	VISH	dz-2	$V_Z < 6.66...6.94 \text{ В}; R_{\theta}(I_Z < 5 \text{ мА}) < 8 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1A2
D11	AZ23C6V8	VISH	dz-2	$V_Z < 6.4...7.2 \text{ В}; R_{\theta}(I_Z < 5 \text{ мА}) < 8 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1A2
D11	AZ23C6V8	TSC	dz-2	$V_Z < 6.4...7.2 \text{ В}; R_{\theta}(I_Z < 5 \text{ мА}) < 8 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1A2
D12	AZ23B7V5	VISH	dz-2	$V_Z < 7.35...7.65 \text{ В}; R_{\theta}(I_Z < 5 \text{ мА}) < 7 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1A2
D12	AZ23C7V5	VISH	dz-2	$V_Z < 7.0...7.9 \text{ В}; R_{\theta}(I_Z < 5 \text{ мА}) < 7 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1A2
D12	AZ23C7V5	TSC	dz-2	$V_Z < 7.0...7.9 \text{ В}; R_{\theta}(I_Z < 5 \text{ мА}) < 7 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1A2
D13	AZ23B8V2	VISH	dz-2	$V_Z < 8.04...8.36 \text{ В}; R_{\theta}(I_Z < 5 \text{ мА}) < 7 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1A2
D13	AZ23C8V2	VISH	dz-2	$V_Z < 7.7...8.7 \text{ В}; R_{\theta}(I_Z < 5 \text{ мА}) < 7 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1A2



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TSM
MFPK TSFP-3

VMT3
VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
D13	AZ23C8V2	TSC	dz-2	$V_2=7.7...8.7\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 7\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D14	AZ23B9V1	WISH	dz-2	$V_2=8.92...9.28\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 10\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D14	AZ23C9V1	WISH	dz-2	$V_2=8.5...9.6\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 10\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D14	AZ23C9V1	TSC	dz-2	$V_2=8.5...9.6\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 10\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D15	AZ23B10	WISH	dz-2	$V_2=9.8...10.2\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 15\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D15	AZ23C10	WISH	dz-2	$V_2=9.4...10.6\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 15\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D15	AZ23C10	TSC	dz-2	$V_2=9.4...10.6\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 15\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D16	AZ23B11	WISH	dz-2	$V_2=10.8...11.2\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 20\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D16	AZ23C11	WISH	dz-2	$V_2=10.4...11.6\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 20\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D16	AZ23C11	TSC	dz-2	$V_2=10.4...11.6\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 20\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D17	AZ23B12	WISH	dz-2	$V_2=11.8...12.2\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 20\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D17	AZ23C12	WISH	dz-2	$V_2=11.4...12.7\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 20\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D17	AZ23C12	TSC	dz-2	$V_2=11.4...12.7\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 20\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D18	AZ23B13	WISH	dz-2	$V_2=12.7...13.3\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 25\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D18	AZ23C13	WISH	dz-2	$V_2=12.4...14.1\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 25\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D18	AZ23C13	TSC	dz-2	$V_2=12.4...14.1\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 25\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D19	AZ23B15	WISH	dz-2	$V_2=14.7...15.3\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 30\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D19	AZ23C15	WISH	dz-2	$V_2=13.8...15.6\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 30\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D19	AZ23C15	TSC	dz-2	$V_2=13.8...15.6\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 30\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D19	KS4812	SAMS	pn-p	$V_{\text{CB0}}=60\text{ В}; I_{\text{c}}=100\text{ мА}; P_{\text{D}}=150\text{ мВт}; h_{21}=200...400; f_{\text{T}} > 180\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
D1L	KS4812	SAMS	pn-p	$V_{\text{CB0}}=60\text{ В}; I_{\text{c}}=100\text{ мА}; P_{\text{D}}=150\text{ мВт}; h_{21}=300...600; f_{\text{T}} > 180\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
D10	KS4812	SAMS	pn-p	$V_{\text{CB0}}=60\text{ В}; I_{\text{c}}=100\text{ мА}; P_{\text{D}}=150\text{ мВт}; h_{21}=90...180; f_{\text{T}} > 180\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
D1p	BCW31	PHIL	npn	$V_{\text{CB0}}=32\text{ В}; I_{\text{c}}=100\text{ мА}; P_{\text{D}}=250\text{ мВт}; h_{21}=110...220; f_{\text{T}} > 100\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
D11	BCW31	PHIL	npn	$V_{\text{CB0}}=32\text{ В}; I_{\text{c}}=100\text{ мА}; P_{\text{D}}=250\text{ мВт}; h_{21}=110...220; f_{\text{T}} > 100\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
D1Y	KS4812	SAMS	pn-p	$V_{\text{CB0}}=60\text{ В}; I_{\text{c}}=100\text{ мА}; P_{\text{D}}=150\text{ мВт}; h_{21}=135...270; f_{\text{T}} > 180\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
D2	AZ23B3V0	WISH	dz-2	$V_2=2.94...3.06\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 95\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D2	AZ23C3V0	WISH	dz-2	$V_2=2.8...3.2\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 95\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D2	AZ23C3V0	TSC	dz-2	$V_2=2.8...3.2\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 95\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D2	BCW32	ALLEG	npn	$V_{\text{CB0}}=30\text{ В}; I_{\text{c}}=100\text{ мА}; h_{21}=200...450; V_{\text{CE(sat)}} < 0.25\text{ В}$	SOT23, SOD23	B-E-C
D2	BCW32	CDIL	npn	$V_{\text{CB0}}=32\text{ В}; I_{\text{c}}=100\text{ мА}; P_{\text{D}}=330\text{ мВт}; h_{21}=200...450; f_{\text{T}} > 300\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
D2	BCW32	ZETEX	npn	$V_{\text{CB0}}=32\text{ В}; I_{\text{c}}=100\text{ мА}; P_{\text{D}}=330\text{ мВт}; h_{21}=200...450; f_{\text{T}} > 300\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
D2	HSMP3802	HP	pin-2	$I_{\text{c}} < 1\text{ А}; V_{\text{BR}} > 100\text{ В}; R_{\text{th}} < 2.0\text{ Ом}; C_{\text{O}} < 0.37\text{ нФ}; R_{\text{th}} > 1000\text{ Ом}; R_{\text{L}} < 8\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
D20	AZ23B16	WISH	dz-2	$V_2=15.7...16.3\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 40\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D20	AZ23C16	WISH	dz-2	$V_2=15.3...17.1\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 40\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D20	AZ23C16	TSC	dz-2	$V_2=15.3...17.1\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 40\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D21	AZ23B18	WISH	dz-2	$V_2=17.6...18.4\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 50\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D21	AZ23C18	WISH	dz-2	$V_2=16.8...19.1\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 50\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D21	AZ23C18	TSC	dz-2	$V_2=16.8...19.1\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 50\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D22	AZ23B20	WISH	dz-2	$V_2=19.6...20.4\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 50\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D22	AZ23C20	WISH	dz-2	$V_2=18.8...21.2\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 50\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D22	AZ23C20	TSC	dz-2	$V_2=18.8...21.2\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 50\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D23	AZ23B22	WISH	dz-2	$V_2=21.6...22.4\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 55\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D23	AZ23C22	WISH	dz-2	$V_2=20.8...23.3\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 55\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D23	AZ23C22	TSC	dz-2	$V_2=20.8...23.3\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 55\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D24	AZ23B24	WISH	dz-2	$V_2=23.5...24.5\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D24	AZ23C24	WISH	dz-2	$V_2=22.8...25.6\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D24	AZ23C24	TSC	dz-2	$V_2=22.8...25.6\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D25	AZ23B27	WISH	dz-2	$V_2=26.5...27.5\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D25	AZ23C27	WISH	dz-2	$V_2=25.1...28.9\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D25	AZ23C27	TSC	dz-2	$V_2=25.1...28.9\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D26	AZ23B30	WISH	dz-2	$V_2=29.4...30.6\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
D26	AZ23C30	WISH	dz-2	$V_2=28...32\text{ В}; R_{\text{pl}}(I_2=5\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
D26	AZ23C30	TSC	dz-2	$V_{z2} = 28...32\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D27	AZ23B33	VISH	dz-2	$V_{z2} = 32.3...33.7\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D27	AZ23C33	VISH	dz-2	$V_{z2} = 31...35\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D27	AZ23C33	TSC	dz-2	$V_{z2} = 31...35\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D28	AZ23B36	VISH	dz-2	$V_{z2} = 35.3...36.7\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 90\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D28	AZ23C36	VISH	dz-2	$V_{z2} = 34...38\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 90\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D28	AZ23C36	TSC	dz-2	$V_{z2} = 34...38\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 90\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D28	BAS70W	STM	shd	$V_{R6} < 70\text{ В}; I_{R6} < 70\text{ мА}; V_{F1}(I_{F1} = 1\text{ мА}) < 0.41\text{ В}; I_{R6} < 0.1\text{ мкА}; C_{D2} < 2.0\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A-n.c.-K
D29	AZ23B39	VISH	dz-2	$V_{z2} = 38.2...39.8\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 90\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D29	AZ23C39	VISH	dz-2	$V_{z2} = 37...41\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 90\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D29	AZ23C39	TSC	dz-2	$V_{z2} = 37...41\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 90\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D29	BAS70-06W	STM	shd-2	$V_{R6} < 70\text{ В}; I_{R6} < 70\text{ мА}; V_{F1}(I_{F1} = 1\text{ мА}) < 0.41\text{ В}; I_{R6} < 0.1\text{ мкА}; C_{D2} < 2.0\text{ нФ}$	SOT323,SC70	K1-K2-A1,A2
D2p	BCW32	PHIL	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_{C2} < 100\text{ мА}; P_{D2} = 250\text{ мВт}; h_{21} > 200...450; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
D2p	BCW32	PHIL	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_{C2} < 100\text{ мА}; P_{D2} = 250\text{ мВт}; h_{21} > 200...450; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
D3	1SS187	TOSH	di	$V_{R6} < 80\text{ В}; I_{R6} < 100\text{ мА}; V_{F1}(I_{F1} = 100\text{ мА}) < 1.2\text{ В}; I_{R6} < 0.5\text{ мкА}; t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOT346,SC59	K-n.c.-A
D3	AZ23B3V3	VISH	dz-2	$V_{z2} = 3.23...3.37\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 95\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D3	AZ23C3V3	VISH	dz-2	$V_{z2} = 3.1...3.5\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 95\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D3	AZ23C3V3	TSC	dz-2	$V_{z2} = 3.1...3.5\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 95\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D3	BCW33	ALLEG	npn	$V_{CEB} = 30\text{ В}; I_{C20} < 100\text{ мА}; h_{21} > 420...800; V_{CEsat} < 0.25\text{ В}$	SOT23,SOD23	B-E-C
D3	BCW33	CDIL	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_{C2} < 100\text{ мА}; P_{D2} = 250\text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
D3	BCW33	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_{C2} < 100\text{ мА}; P_{D2} = 330\text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
D30	AZ23B43	VISH	dz-2	$V_{z2} = 42.1...43.9\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D30	AZ23C43	VISH	dz-2	$V_{z2} = 40...46\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D30	AZ23C43	DIODS	dz-2	$V_{z2} = 40...46\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D30	AZ23C43	TSC	dz-2	$V_{z2} = 40...46\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D30	BAS70-05W	STM	shd-2	$V_{R6} < 70\text{ В}; I_{R6} < 70\text{ мА}; V_{F1}(I_{F1} = 1\text{ мА}) < 0.41\text{ В}; I_{R6} < 0.1\text{ мкА}; C_{D2} < 2.0\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1-A2-K1,K2
D31	AZ23B47	VISH	dz-2	$V_{z2} = 46.1...47.9\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D31	AZ23C47	VISH	dz-2	$V_{z2} = 44...50\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D31	AZ23C47	DIODS	dz-2	$V_{z2} = 44...50\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D31	AZ23C47	TSC	dz-2	$V_{z2} = 44...50\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D31	BAS70-04W	STM	shd-2	$V_{R6} < 70\text{ В}; I_{R6} < 70\text{ мА}; V_{F1}(I_{F1} = 1\text{ мА}) < 0.41\text{ В}; I_{R6} < 0.1\text{ мкА}; C_{D2} < 2.0\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1-K2-K1,A2
D32	AZ23B51	VISH	dz-2	$V_{z2} = 50...52\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D32	AZ23C51	VISH	dz-2	$V_{z2} = 48...54\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D32	AZ23C51	DIODS	dz-2	$V_{z2} = 48...54\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D32	AZ23C51	TSC	dz-2	$V_{z2} = 48...54\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D3B	RB420D	ROHM	shd	$V_{R6} < 40\text{ В}; I_{R6} < 100\text{ мА}; V_{F1}(I_{F1} = 10\text{ мА}) < 450\text{ мВ}; C_{D2} = 6\text{ нФ}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
D3E	RB411D	ROHM	shd	$V_{R6} < 20\text{ В}; I_{R6} < 500\text{ мА}; V_{F1}(I_{F1} = 500\text{ мА}) < 500\text{ мВ}; C_{D2} = 20\text{ нФ}$	SOT346,SC59	A-n.c.-K
D3J	RB706D-40	ROHM	shd-2	$V_{R6} < 40\text{ В}; I_{R6} < 30\text{ мА}; V_{F1}(I_{F1} = 1\text{ мА}) < 370\text{ мВ}; C_{D2} = 2\text{ нФ}$	SOT346,SC59	A1-K1,A2-K2
D3p	BCW33	PHIL	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_{C2} < 100\text{ мА}; P_{D2} = 250\text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
D3t	BCW33	PHIL	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_{C2} < 100\text{ мА}; P_{D2} = 250\text{ мВт}; h_{21} > 420...800; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
D4	AZ23B3V6	VISH	dz-2	$V_{z2} = 3.53...3.67\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 95\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D4	AZ23C3V6	VISH	dz-2	$V_{z2} = 3.4...3.8\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 95\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D4	AZ23C3V6	TSC	dz-2	$V_{z2} = 3.4...3.8\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 95\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D4	BCW31R	PHIL	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_{C2} < 100\text{ мА}; P_{D2} = 350\text{ мВт}; h_{21} > 110...220; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	E-B-C
D4	BCW31R	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 32\text{ В}; I_{C2} < 100\text{ мА}; P_{D2} = 330\text{ мВт}; h_{21} > 110...220; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
D4	H5MP3804	HP	pim-2	$I_{R6} < 1\text{ А}; V_{R6} > 100\text{ В}; R_{R6} < 2.0\text{ Ом}; C_{D2} < 0.37\text{ нФ}; R_{R1} > 1000\text{ Ом}; R_{R2} < 8\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
D46	BAT46W	STM	shd	$V_{R6} < 100\text{ В}; I_{R6} < 150\text{ мА}; V_{F1}(I_{F1} = 10\text{ мА}) < 0.45\text{ мВ}; C_{D2} = 10\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A-n.c.-K
D49	CMFD5001S	CSI	dih-2	$I_{R6} = 400\text{ мА}; V_{R6} = 120\text{ В}; V_{F1}(I_{F1} = 100\text{ мА}) < 0.9\text{ В}; I_{R6} < 100\text{ нА}; t_{RR} < 50\text{ нс}; C_T = 35\text{ пФ}$	SOT23,SOD23	A2-K1-K2,A1
D4	AZ23B3V9	VISH	dz-2	$V_{z2} = 3.82...3.98\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 95\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D5	AZ23C3V9	VISH	dz-2	$V_{z2} = 3.7...4.1\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 95\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
D5	AZ23C3V9	TSC	dz-2	$V_{z2} = 3.7...4.1\text{ В}; R_{z1}(I_{z2} = 5\text{ мА}) < 95\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
D5	BCW32R	PHIL	npn	$V_{CE0} > 32 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 200 \dots 450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	Е•В•С
D5	BCW32R	ZETEX	npn	$V_{CE0} > 32 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 200 \dots 450; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
D53	CMPPD2004	CSI	fid	$I_C < 225 \text{ мА}; V_{BE} < 240 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_B < 100 \text{ мА}; I_{BEM} < 50 \text{ нС}; C_T < 5.0 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	А•н.с.•К
D58	FLLD258	ZETEX	d-z	$V_B < 100 \text{ В}; I_C < 250 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1.4 \text{ В}; I_B < 5 \text{ мкА}; C_D < 4 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
D5s	BBV57-05W	INF	var	$V_B < 10 \text{ В}; I_C < 20 \text{ мА}; I_B < 0.01 \text{ мА}; C_{1B} < 16.5 \dots 18.6 \text{ нФ}; C_{1B} < 3.5 \dots 5.5 \text{ пФ}$	SOT323, SC70	A1•A2•K1, K2
D6	AZ23B4V3	WISH	dz-2	$V_2 < 4.21 \dots 4.39 \text{ В}; R_{D1}(I_C = 5 \text{ мА}) < 95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
D6	AZ23CAV3	WISH	dz-2	$V_2 < 4.0 \dots 4.6 \text{ В}; R_{D1}(I_C = 5 \text{ мА}) < 95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
D6	AZ23CAV3	TSC	dz-2	$V_2 < 4.0 \dots 4.6 \text{ В}; R_{D1}(I_C = 5 \text{ мА}) < 95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
D6	BCW33R	PHIL	npn	$V_{CE0} > 32 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 200 \dots 800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	Е•В•С
D6	BCW33R	ZETEX	npn	$V_{CE0} > 32 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 200 \dots 800; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
D6	MMBC1622D6	MOT	npn	$V_{CE0} > 40 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 300 \text{ мВт}; h_{21} > 200 \dots 400$	SOT23, SOD23	В•Е•С
D63	FLLD263	ZETEX	d-z	$V_B < 100 \text{ В}; I_C < 250 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1.4 \text{ В}; I_B < 5 \text{ мкА}; C_D < 4 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
D7	AZ23B4V7	WISH	dz-2	$V_2 < 4.61 \dots 4.79 \text{ В}; R_{D1}(I_C = 5 \text{ мА}) < 78 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
D7	AZ23CAV7	WISH	dz-2	$V_2 < 4.4 \dots 5.0 \text{ В}; R_{D1}(I_C = 5 \text{ мА}) < 78 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
D7	AZ23CAV7	TSC	dz-2	$V_2 < 4.4 \dots 5.0 \text{ В}; R_{D1}(I_C = 5 \text{ мА}) < 78 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
D7	MMBC1622D7	MOT	npn	$V_{CE0} > 40 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 300 \text{ мВт}; h_{21} > 300 \dots 600$	SOT23, SOD23	В•Е•С
D73	BAT54W	STM	shd	$V_B < 30 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 100 \text{ мА}) < 0.9 \text{ В}; I_B < 1 \text{ мкА}; C_D < 10 \text{ нФ}; I_{BEM} < 5 \text{ нС}$	SOT323, SC70	А•н.с.•К
D74	BAT54AW	STM	shd-2	$V_B < 30 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 100 \text{ мА}) < 0.9 \text{ В}; I_B < 4.0 \text{ мкА}; C_D < 10 \text{ нФ}; I_{BEM} < 5 \text{ нС}$	SOT323, SC70	K1•K2•A2, A1
D76	BAR18	ALLEG	shd	$V_{BE} > 70 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 1 \text{ мА}) < 0.41 \text{ В}; I_B < 200 \text{ нА}; C_T < 1.7 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	А•н.с.•К
D76	BAR18	STM	shd	$V_{BE} > 70 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 1 \text{ мА}) < 0.41 \text{ В}; I_B < 200 \text{ нА}$	SOT23, SOD23	А•н.с.•К
D76	CMPPD263	CSI	shd	$I_C < 15 \text{ мА}; V_{BEM} < 70 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 1 \text{ мА}) < 0.395 \dots 0.410 \text{ В}; I_B < 200 \text{ нА}; C_T < 2.0 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	А•н.с.•К
D77	BAT54CW	STM	shd-2	$V_B < 30 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 100 \text{ мА}) < 0.9 \text{ В}; I_B < 1 \text{ мкА}; C_D < 10 \text{ нФ}; I_{BEM} < 5 \text{ нС}$	SOT323, SC70	A1•A2•K1, K2
D77	BCF32R	PHIL	npn	$V_{CE0} > 20 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 200; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	Е•В•С
D78	BAT54SW	STM	shd-2	$V_B < 30 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 100 \text{ мА}) < 0.9 \text{ В}; I_B < 1 \text{ мкА}; C_D < 10 \text{ нФ}; I_{BEM} < 5 \text{ нС}$	SOT323, SC70	A1•K2•K1, A2
D7p	BCF32	PHIL	npn	$V_{CE0} > 32 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 200 \dots 450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
D7l	BCF32	PHIL	npn	$V_{CE0} > 32 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 200 \dots 450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
D8	AZ23B5V1	WISH	dz-2	$V_2 < 5.0 \dots 5.2 \text{ В}; R_{D1}(I_C = 5 \text{ мА}) < 60 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
D8	AZ23C5V1	WISH	dz-2	$V_2 < 4.8 \dots 5.4 \text{ В}; R_{D1}(I_C = 5 \text{ мА}) < 60 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
D8	AZ23C5V1	TSC	dz-2	$V_2 < 4.8 \dots 5.4 \text{ В}; R_{D1}(I_C = 5 \text{ мА}) < 60 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
D81	BCF33R	PHIL	npn	$V_{CE0} > 20 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 420; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	Е•В•С
D84	BAT54A	STM	shd-2	$V_B < 30 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 100 \text{ мА}) < 0.9 \text{ В}; I_B < 4.0 \text{ мкА}; C_D < 10 \text{ нФ}; I_{BEM} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
D86	BAT54	STM	shd	$V_B < 30 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 100 \text{ мА}) < 0.9 \text{ В}; I_B < 1 \text{ мкА}; C_D < 10 \text{ нФ}; I_{BEM} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	А•н.с.•К
D87	BAT54C	STM	shd-2	$V_B < 30 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 100 \text{ мА}) < 0.9 \text{ В}; I_B < 4.0 \text{ мкА}; C_D < 10 \text{ нФ}; I_{BEM} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
D88	BAT54S	STM	shd-2	$V_B < 30 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 100 \text{ мА}) < 0.9 \text{ В}; I_B < 4.0 \text{ мкА}; C_D < 10 \text{ нФ}; I_{BEM} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1•K2•K1, A2
D8p	BCF33	PHIL	npn	$V_{CE0} > 32 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 200 \dots 800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
D9	1SS401	TOSH	shd	$V_B > 20 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 300 \text{ мА}) < 0.45 \text{ В}; I_B(V_B = 20 \text{ В}) < 50 \text{ мкА}; C_T < 46 \text{ нФ}$	SOT323, SC70	А•н.с.•К
D9	AZ23B5V6	WISH	dz-2	$V_2 < 5.49 \dots 5.71 \text{ В}; R_{D1}(I_C = 5 \text{ мА}) < 40 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
D9	AZ23C5V6	WISH	dz-2	$V_2 < 5.2 \dots 6.0 \text{ В}; R_{D1}(I_C = 5 \text{ мА}) < 40 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
D9	AZ23C5V6	TSC	dz-2	$V_2 < 5.2 \dots 6.0 \text{ В}; R_{D1}(I_C = 5 \text{ мА}) < 40 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
D94	BAR42	STM	shd	$V_{BE} > 30 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 50 \text{ мА}) < 0.66 \text{ В}; I_B < 100 \text{ мкА}; C_T < 7 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	А•н.с.•К
D95	BAR43	STM	shd	$V_{BE} > 30 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 15 \text{ мА}) < 0.45 \text{ В}; I_B < 100 \text{ мкА}; C_T < 7 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	А•н.с.•К
D96	CMPSH3	CSI	shd	$I_C < 100 \text{ мА}; V_{BEM} < 30 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_B < 500 \text{ нА}; C_T < 7.0 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	А•н.с.•К
D96	BAS70-04	STM	shd-2	$V_{BE} > 70 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 1 \text{ мА}) < 0.41 \text{ В}; I_B < 200 \text{ нА}$	SOT23, SOD23	A2•K1•K2, A1
D96	CMPPD263S	CSI	shd-2	$I_C < 15 \text{ мА}; V_{BEM} < 70 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 1 \text{ мА}) < 0.395 \dots 0.410 \text{ В}; I_B < 200 \text{ нА}; C_T < 2.0 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A2•K1•K2, A1
D97	BAS70-05	STM	shd-2	$V_{BE} > 70 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 1 \text{ мА}) < 0.41 \text{ В}; I_B < 200 \text{ нА}$	SOT23, SOD23	A2•A1•K2, K1
D97	CMPPD263C	CSI	shd-2	$I_C < 15 \text{ мА}; V_{BEM} < 70 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 1 \text{ мА}) < 0.395 \dots 0.410 \text{ В}; I_B < 200 \text{ нА}; C_T < 2.0 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A2•A1•K2, K1
D98	BAS70-06	STM	shd-2	$V_{BE} > 70 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 1 \text{ мА}) < 0.41 \text{ В}; I_B < 200 \text{ нА}$	SOT23, SOD23	K2•K1•A2, A1
D98	CMPPD263A	CSI	shd-2	$I_C < 15 \text{ мА}; V_{BEM} < 70 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 1 \text{ мА}) < 0.395 \dots 0.410 \text{ В}; I_B < 200 \text{ нА}; C_T < 2.0 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K2•K1•A2, A1

**SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3**

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
DA	BCW67A	ALLEG	pnp	$V_{CEB} < 45 \text{ В}; I_{CB} < 20 \text{ мА}; I_{H1} > 100 \dots 250; V_{CE(sat)} < 0.7 \text{ В}; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DA	BCW67A	CDIL	pnp	$V_{CEB} < 45 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 100 \dots 250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DA	BCW67A	ZETEX	pnp	$V_{CEB} < 45 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 100 \dots 250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DA	MMBZ4708	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT})} = 50 \text{ мкА} < 20.9 \dots 23.1 \text{ В}; I_{SK} < 0.01 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A•n.c. •K
DA2	CMPD5001	CSI	dih	$I_E = 400 \text{ мА}; V_{F1} = 120 \text{ В}; V_{F1(I_E)} = 100 \text{ мА} < 0.9 \text{ В}; I_{SK} < 100 \text{ нА}; t_{BR} < 50 \text{ нс}; C_T < 35 \text{ пФ}$	SOT23,SOD23	A•n.c. •K
DA5	BAR43S	STM	shd-2	$V_{BR} > 30 \text{ В}; V_{F1(I_E)} = 15 \text{ мА} < 0.45 \text{ В}; I_{SK} < 100 \text{ мкА}; C_T = 7 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A2-K1•K2,A1
DA5	CMPSH3S	CSI	shd-2	$I_E = 100 \text{ мА}; V_{FEM} = 30 \text{ В}; V_{F1(I_E)} = 100 \text{ мА} < 1.00 \text{ В}; I_{SK} < 500 \text{ нА}; C_T = 2.0 \text{ нФ}; t_{BR} < 5.0 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A2-K1•K2,A1
DA5	BCW67A	SIEM	pnp	$V_{CEB} < 45 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 100 \dots 250; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DB	BCW67B	ALLEG	pnp	$V_{CEB} < 45 \text{ В}; I_{CB} < 20 \text{ мА}; I_{H1} > 160 \dots 400; V_{CE(sat)} < 0.7 \text{ В}; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DB	BCW67B	CDIL	pnp	$V_{CEB} < 45 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 160 \dots 400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DB	BCW67B	ZETEX	pnp	$V_{CEB} < 45 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 160 \dots 400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DB	BCW67B	SGS	pnp	$V_{CEB} < 45 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 160 \dots 400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DB1	BAR43A	STM	shd-2	$V_{BR} > 30 \text{ В}; V_{F1(I_E)} = 15 \text{ мА} < 0.45 \text{ В}; I_{SK} < 100 \text{ мкА}; C_T = 7 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K2-K1•A1,A2
DB1	CMPSH3A	CSI	shd-2	$I_E = 100 \text{ мА}; V_{FEM} = 30 \text{ В}; V_{F1(I_E)} = 100 \text{ мА} < 1.00 \text{ В}; I_{SK} < 500 \text{ нА}; C_T = 2.0 \text{ нФ}; t_{BR} < 5.0 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	K2-K1•A2,A1
DB2	BAR43C	STM	shd-2	$V_{BR} > 30 \text{ В}; V_{F1(I_E)} = 15 \text{ мА} < 0.45 \text{ В}; I_{SK} < 100 \text{ мкА}; C_T = 7 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A2-A1•K1,K2
DB2	CMPSH3C	CSI	shd-2	$I_E = 100 \text{ мА}; V_{FEM} = 30 \text{ В}; V_{F1(I_E)} = 100 \text{ мА} < 1.00 \text{ В}; I_{SK} < 500 \text{ нА}; C_T = 2.0 \text{ нФ}; t_{BR} < 5.0 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A2-A1•K2,K1
DB6	BAT46AW	STM	shd-2	$V_{AK} < 100 \text{ В}; I_C < 150 \text{ мА}; V_{F1(I_C)} = 10 \text{ мА} < 0.45 \text{ мВ}; C_D > 10 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	K2-K1•A1,A2
DB6	CMPD2004S	CSI	fhv-2	$I_C < 225 \text{ мА}; V_{AK} = 240 \text{ В}; V_{F1(I_C)} = 100 \text{ мА} < 1.0 \text{ В}; I_{SK} < 100 \text{ нА}; t_{BR} < 50 \text{ нс}; C_T < 5.0 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A2-K1•K2,A1
DB5	BCW67B	SIEM	pnp	$V_{CEB} < 45 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 160 \dots 400; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DC	BCW67C	CDIL	pnp	$V_{CEB} < 45 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 250 \dots 630; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DC	BCW67C	ZETEX	pnp	$V_{CEB} < 45 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 250 \dots 630; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DC	BCW67C	SGS	pnp	$V_{CEB} < 45 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 250 \dots 630; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DC	MMBZ4695	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT})} = 50 \text{ мкА} < 8.27 \dots 9.14 \text{ В}; I_{SK} < 1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A•n.c. •K
DC5	BCW67C	SIEM	pnp	$V_{CEB} < 45 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 250 \dots 630; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DD	2SC2463D	REN	nnpn	$V_{CEB} < 55 \text{ В}; I_{CB} < 100 \text{ мА}; P_D > 150 \text{ мВт}; I_{H1} > 250 \dots 500$	SOT23,SOD23	B•E•C
DD	MMBZ4696	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT})} = 50 \text{ мкА} < 8.65 \dots 9.56 \text{ В}; I_{SK} < 1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A•n.c. •K
DE	2SA1037AKLNE	ROHM	pnp	$V_{CEB} < 50 \text{ В}; I_{CB} < 150 \text{ мА}; P_D > 200 \text{ мВт}; I_{H1} > 390 \dots 820; f_T > 140 \text{ МГц}$	SOT346,SC59	B•E•C
DE	2SC2463E	REN	nnpn	$V_{CEB} < 55 \text{ В}; I_{CB} < 100 \text{ мА}; P_D > 150 \text{ мВт}; I_{H1} > 400 \dots 800$	SOT23,SOD23	B•E•C
DE	MMBZ4697	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT})} = 50 \text{ мкА} < 9.5 \dots 10.5 \text{ В}; I_{SK} < 1 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A•n.c. •K
DF	BCW68F	ALLEG	pnp	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_{CB} < 20 \text{ мА}; I_{H1} > 100 \dots 250; V_{CE(sat)} < 0.7 \text{ В}; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DF	BCW68F	CDIL	pnp	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 100 \dots 250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DF	BCW68F	ZETEX	pnp	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 100 \dots 250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DF	BCW68F	SGS	pnp	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 100 \dots 250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DF	MMBZ4698	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT})} = 50 \text{ мкА} < 10.5 \dots 11.6 \text{ В}; I_{SK} < 0.05 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A•n.c. •K
DF5	BCW68F	SIEM	pnp	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 100 \dots 250; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DG	BCW68G	ALLEG	pnp	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_{CB} < 20 \text{ мА}; I_{H1} > 160 \dots 400; V_{CE(sat)} < 0.7 \text{ В}; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DG	BCW68G	CDIL	pnp	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 160 \dots 400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DG	BCW68G	ZETEX	pnp	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 160 \dots 400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DG	BCW68G	SGS	pnp	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 160 \dots 400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DG	BRC124ECM	REN	Dnpn	$V_{CC} < 50 \text{ В}; I_{OUT} = 100 \text{ мА}; P_D > 150 \text{ мВт}; I_{H1} > 56; 22 \text{ к}/22 \text{ к}$	SOT323,SC70	B•E•C
DG	BRC124EMP	REN	Dnpn	$V_{CC} < 50 \text{ В}; I_{OUT} = 100 \text{ мА}; P_D > 150 \text{ мВт}; I_{H1} > 56; 22 \text{ к}/22 \text{ к}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DG5	BCW68G	SIEM	pnp	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 160 \dots 400; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DH	BCW68G	MOT	pnp	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 160 \dots 400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DH	BCW68H	CDIL	pnp	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 250 \dots 630; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DH	BCW68H	ZETEX	pnp	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 250 \dots 630; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DH	BCW68H	SGS	pnp	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_{CB} < 800 \text{ мА}; P_D > 330 \text{ мВт}; I_{H1} > 250 \dots 630; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
DH	MMBD2000T1	MOT	di	$V_A < 30 \text{ В}; I_F < 200 \text{ мА}; V_{F1(I_F)} = 10 \text{ мА} < 0.95 \text{ В}; C_D < 2 \text{ нФ}; t_{BR} < 3 \text{ нс}$	SOT323,SC70	A•n.c. •K
DH	MMBZ4699	VISH	dz	$V_{Z(I_{ZT})} = 50 \text{ мкА} < 11.4 \dots 12.6 \text{ В}; I_{SK} < 0.05 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A•n.c. •K



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	СИМ	Ф	Особенности	Корпус	В: С+2*3
DHs	BCW68H	SIEM	pnp	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{FE1} = 250...630$; $f_T = 200$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
DI	25C3867	REN	npn	$V_{CE0} = 20$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{FE1} = 20...200$; $f_T > 1.4$ ГГц	SOT346, SC59	E-B-C
DI	MMBZ2005T1	MOT	di-2	$V_{R0} = 30$ В; $I_C = 200$ мА; $V_{F1}(I_F = 10$ мА) $< 0,95$ В	SOT23, SOT346	K1-K2-A1, A2
DJ	MMBZ4700	VISH	dz	$V_2(I_{Z1} = 50$ мкА) $= 12.4...13.7$ В; $I_S < 0.05$ мкА	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
DK	MMBZ4701	VISH	dz	$V_2(I_{Z1} = 50$ мкА) $= 13.3...14.7$ В; $I_S < 0.05$ мкА	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
DKs	BCY42	SIEM	pnp	$V_{CE0} = 125$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{FE1} > 63$; $f_T = 150$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
DM	MMBZ4702	VISH	dz	$V_2(I_{Z1} = 50$ мкА) $= 14.3...15.8$ В; $I_S < 0.05$ мкА	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
DN	25K3349	REN	nMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_D = 50$ мА; $P_D = 100$ мВт; $R_{DS(on)} < 7.2$ Ом	SOT416, SC75A	G-S-D
DN	MMBZ4703	VISH	dz	$V_2(I_{Z1} = 50$ мкА) $= 15.2...16.8$ В; $I_S < 0.05$ мкА	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
DP	2S, J567	REN	pMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_D = 50$ мА; $P_D = 100$ мВт; $R_{DS(on)} < 8.5$ Ом	SOT416, SC75A	G-S-D
DP	MMB20210	MOT	di-2	$V_{R0} = 30$ В; $I_C = 200$ мА; $V_{F1}(I_F = 10$ мА) $< 0,95$ В; $C_D < 2$ нФ; $t_{sp} < 3$ нс	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
DP	MMBZ4704	VISH	dz	$V_2(I_{Z1} = 50$ мкА) $= 16.2...17.9$ В; $I_S < 0.05$ мкА	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
DQ	2PB1219AQ	PHIL	pnp	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{FE1} = 85...170$; $f_T > 100$ МГц	SOT323, SOT70	B-E-C
DQ	2PB710AQ	PHIL	pnp	$V_{CE0} = 50$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{FE1} = 85...170$; $f_T > 100$ МГц	SOT346, SC59	B-E-C
DR	2PB1219AR	PHIL	pnp	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{FE1} = 120...240$; $f_T > 120$ МГц	SOT323, SOT70	B-E-C
DR	2PB710AR	PHIL	pnp	$V_{CE0} = 50$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{FE1} = 120...240$; $f_T > 120$ МГц	SOT346, SC59	B-E-C
DR	2SA1037AKLNR	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 50$ В; $I_C = 150$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{FE1} = 180...390$; $f_T > 140$ МГц	SOT346, SC59	B-E-C
DR	BCW60BR	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 32$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{FE1} = 180...310$; $f_T > 250$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
DS	2PB1219AS	PHIL	pnp	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{FE1} = 170...340$; $f_T > 140$ МГц	SOT323, SOT70	B-E-C
DS	2PB710AS	PHIL	pnp	$V_{CE0} = 50$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 250$ мВт; $h_{FE1} = 170...340$; $f_T > 140$ МГц	SOT346, SC59	B-E-C
DS	2SA1037AKLNS	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 50$ В; $I_C = 150$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{FE1} = 270...560$; $f_T > 140$ МГц	SOT346, SC59	B-E-C
DT	BCW67AR	SGS	pnp	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{FE1} = 100...250$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	C-B-E
DT	MMBZ4705	VISH	dz	$V_2(I_{Z1} = 50$ мкА) $= 17.1...18.9$ В; $I_S < 0.05$ мкА	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
DU	BCW67BR	SGS	pnp	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{FE1} = 160...400$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	C-B-E
DU	MMBZ4706	VISH	dz	$V_2(I_{Z1} = 50$ мкА) $= 18.1...20.0$ В; $I_S < 0.05$ мкА	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
DV	MMBZ4707	VISH	dz	$V_2(I_{Z1} = 50$ мкА) $= 19.0...21.0$ В; $I_S < 0.01$ мкА	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
DW	BCW67CR	SGS	pnp	$V_{CE0} = 45$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{FE1} = 250...630$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	C-B-E
DX	BCW68FR	SGS	pnp	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{FE1} = 100...250$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	C-B-E
DY	BCW68GR	SGS	pnp	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{FE1} = 160...400$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	C-B-E
DY	MMBZ4710	VISH	dz	$V_2(I_{Z1} = 50$ мкА) $= 23.8...26.3$ В; $I_S < 0.01$ мкА	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
DZ	BCW68HR	SGS	pnp	$V_{CE0} = 60$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{FE1} = 250...630$; $f_T > 100$ МГц	SOT23, SOD23	C-B-E
DZ	MMBZ4709	VISH	dz	$V_2(I_{Z1} = 50$ мкА) $= 22.8...25.2$ В; $I_S < 0.01$ мкА	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
E	1SS780	ROHM	sw	40 В; 100 мА I _o leakage	SOT416, SC75	A-K
E	IRLML6402	IR	pMOS	HEXFET; $V_{DS} = 20$ В; $I_D = 2.2$ А; $P_D = 1.3$ Вт; $R_{DS(on)} < 0.135$ Ом	SOT23, SOD23	G-S-D
E0	HSPM3810	HP	pin	$I_C = 1$ А; $V_{BE} > 100$ В; $R_{BE} < 3.0$ Ом; $C_D < 0.35$ нФ; $R_{th} > 1500$ Ом; $R_C < 10$ Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
E0	HSPM381B	HP	pin	$I_C = 1$ А; $V_{BE} > 100$ В; $R_{BE} < 3.0$ Ом; $CT < 0.35$ нФ; $R_{th} > 1500$ Ом; $R_C < 10$ Ом	SOT323, SOT70	A-n.c.-K
E1	BFS17	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 25$ В; $I_C = 25$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{FE1} = 25...150$; $f_T > 1000$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
E1	BFS17	TELEF	npn	$V_{CE0} = 25$ В; $I_C = 25$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{FE1} = 20...150$; $f_T > 1000$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
E1	BFS17LT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 15$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{FE1} = 20...150$; $f_T > 1000$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
E1	HSPM3811	HP	pin	$I_C = 1$ А; $V_{BE} > 100$ В; $R_{BE} < 3.0$ Ом; $C_D < 0.35$ нФ; $R_{th} > 1500$ Ом; $R_C < 10$ Ом	SOT23, SOD23	n.c.-A-K
E1	MMBZ5231BT	DIODS	dz	$V_2(I_{Z1} = 20$ мА) $= 4.85...5.36$ В; $I_S < 5$ мкА	SOT523	A-n.c.-K
E11	DTA1132E	ROHM	Dnpnp	$V_{CE0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{FE1} > 33$; $f_T > 250$ МГц; $R_{F1}/R_{F2} = 1/10$ КОМ	SOT416, SC75A	B-E-C
E11	DTA1132KA	ROHM	Dnpnp	$V_{CE0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{FE1} > 33$; $f_T > 250$ МГц; $R_{F1}/R_{F2} = 1/10$ КОМ	SOT346, SC59	B-E-C
E13	DTA1432E	ROHM	Dnpnp	$V_{CE0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{FE1} > 80$; $f_T > 250$ МГц; $R_{F1}/R_{F2} = 4.7/47$ КОМ	SOT416, SC75A	B-E-C
E13	DTA1432KA	ROHM	Dnpnp	$V_{CE0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{FE1} > 80$; $f_T > 250$ МГц; $R_{F1}/R_{F2} = 4.7/47$ КОМ	SOT346, SC59	B-E-C
E1H	BFS17H	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 25$ В; $I_C = 25$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{FE1} = 70...200$; $f_T > 1000$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
E1L	BFS17L	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 25$ В; $I_C = 25$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{FE1} = 25...100$; $f_T > 1000$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
E10	KSC2859	SAMS	npn	$V_{CE0} = 35$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{FE1} = 70...140$; $f_T > 300$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
E1p	BFS17	PHIL	npn	$V_{CE0} = 25$ В; $I_C = 25$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{FE1} = 25...150$; $f_T > 1000$ МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
E1p	BFS17W	PHIL	npn	$V_{CE0} = 25$ В; $I_C = 25$ мА; $P_D = 330$ мВт; $h_{FE1} = 25...150$; $f_T > 1000$ МГц	SOT323, SOT70	B-E-C

**SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3**

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
E1Y	KSC2859	SAMS	npn	$V_{CEB} < 35 В; I_C < 500 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} > 120...240; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
E2	BAL99	ZETEX	di	$V_A < 70 В; I_F < 100 мА; V_{F(I_F=50 мА)} < 1.1 В; I_S < 2.5 мкА; C_D < 1.5 нФ; I_{RR} < 6 мА$	SOT23, SOD23	n.c. • K • A
E2	BFS17A	TELEF	npn	$V_{CEB} < 25 В; I_C < 25 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 200...150; f_T > 1000 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
E2	HSMF3812	HP	pin-2	$I_F < 1 А; V_{BE} > 100 В; R_{\theta C} < 2.0 °С/мВт; C_D < 0.37 нФ; R_{th} > 1000 °С/м; R_{\theta C} < 8 °С/м$	SOT23, SOD23	A1 • K2 • K1, A2
E2	HSMF381C	HP	pin-2	$I_F < 1 А; V_{BE} > 100 В; R_T < 3.0 °С/м; CT < 0.35 нФ; R_{th} > 1500 °С/м; R_{\theta C} < 10 °С/м$	SOT323, SC70	A1 • K2 • A2, K1
E2	MMBZ5232BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}=20 мА) = 5.32...5.88 В; I_{S1} < 5 мкА$	SOT523	A • n.c. • K
E21	DTC1132E	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} > 33; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 1/10 кОм$	SOT416, SC75A	B•E•C
E21	DTC1132KA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 33; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 1/10 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
E23	DTC1432CA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} > 80; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7/47 кОм$	SOT23, SOD23	B•E•C
E23	DTC1432E	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} > 80; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7/47 кОм$	SOT416, SC75A	B•E•C
E23	DTC1432KA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 80; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7/47 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
E3	1SS190	TOSH	di	$V_A < 80 В; I_F < 100 мА; V_{F(I_F=100 мА)} < 1.2 В; I_S < 0.5 мкА; I_{RR} < 4 мА$	SOT346, SC59	n.c. • K • A
E3	2SA1688	SANYO	npn	$V_{CEB} < 30 В; I_C < 30 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} > 60...120; f_T > 320 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
E3	BAR99	ZETEX	di	$V_A < 70 В; I_F < 100 мА; V_{F(I_F=50 мА)} < 1.1 В; I_S < 2.5 мкА; C_D < 1.5 нФ; I_{RR} < 6 мА$	SOT23, SOD23	n.c. • n.c. • A
E3	HSMF3813	HP	pin-2	$I_F < 1 А; V_{BE} > 100 В; R_{\theta C} < 2.0 °С/мВт; C_D < 0.37 нФ; R_{th} > 1000 °С/м; R_{\theta C} < 8 °С/м$	SOT23, SOD23	K1 • K2 • A1, A2
E3	HSMF381E	HP	pin-2	$I_F < 1 А; V_{BE} > 100 В; R_T < 3.0 °С/м; CT < 0.35 нФ; R_{th} > 1500 °С/м; R_{\theta C} < 10 °С/м$	SOT323, SC70	K1 • K2 • A1, A2
E32	DTA123JE	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} > 80; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 2.2/47 кОм$	SOT416, SC75A	B•E•C
E32	DTA123JKA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 80; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 2.2/47 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
E4	2SA1688	SANYO	npn	$V_{CEB} < 30 В; I_C < 30 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} > 90...180; f_T > 320 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
E4	BFS17R	PHIL	npn	$V_{CEB} < 25 В; I_C < 25 мА; P_D < 330 мВт; h_{21} > 250...150; f_T > 1000 МГц$	SOT23, SOD23	C•B•E
E4	BFS17R	TELEF	npn	$V_{CEB} < 25 В; I_C < 25 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 200...150; f_T > 1000 МГц$	SOT23, SOD23	C•B•E
E4	HSMF3814	HP	pin-2	$I_F < 1 А; V_{BE} > 100 В; R_{\theta C} < 2.0 °С/мВт; C_D < 0.37 нФ; R_{th} > 1000 °С/м; R_{\theta C} < 8 °С/м$	SOT23, SOD23	K1 • A2 • K1, K2
E4	HSMF381F	HP	pin-2	$I_F < 1 А; V_{BE} > 100 В; R_T < 3.0 °С/м; CT < 0.35 нФ; R_{th} > 1500 °С/м; R_{\theta C} < 10 °С/м$	SOT323, SC70	A1 • A2 • K1, K2
E4	MMBZ5234BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}=20 мА) = 5.89...6.51 В; I_{S1} < 5 мкА$	SOT523	A • n.c. • K
E42	DTC123JE	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} > 80; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 2.2/47 кОм$	SOT416, SC75A	B•E•C
E42	DTC123JKA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 80; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 2.2/47 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
E42	DTC123JUA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 80; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 2.2/47 кОм$	SOT323, SC70	B•E•C
E5	2SA1688	SANYO	npn	$V_{CEB} < 30 В; I_C < 30 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} > 135...270; f_T > 320 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
E5	BFS17AR	TELEF	npn	$V_{CEB} < 25 В; I_C < 25 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 200...150; f_T > 1000 МГц$	SOT23, SOD23	C•B•E
E5	MMBZ5235BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}=20 мА) = 6.46...7.14 В; I_{S1} < 3 мкА$	SOT523	A • n.c. • K
E56	DTA144VE	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} > 33; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 47/10 кОм$	SOT416, SC75A	B•E•C
E56	DTA144VKA	ROHM	npn	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 33; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 47/10 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
E56	DTA144VUA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 33; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 47/10 кОм$	SOT323, SC70	B•E•C
E66	ZC2800E	ZETEX	shd	$V_A < 75 В; V_{F(I_F=1 мА)} < 0.41 В; I_S < 0.2 мкА; C_D < 2.0 нФ$	SOT23, SOD23	A • n.c. • K
E66	DTA144VE	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} > 33; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 47/10 кОм$	SOT416, SC75A	B•E•C
E66	DTC144VKA	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 33; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 47/10 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
E79	DTA115UK	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 27; f_T > 250 МГц$	SOT346, SC59	B•E•C
E8	PDTB123YK	PHIL	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 500 мА; P_D < 250 мВт; h_{21} > 70; 2.2 кОм/10 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
E8	ZC2811E	ZETEX	shd	$V_A < 15 В; V_{F(I_F=1 мА)} < 0.41 В; I_S < 0.1 мкА; C_D < 1.2 нФ$	SOT23, SOD23	A • n.c. • K
E89	DTC115UK	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 27; f_T > 250 МГц$	SOT346, SC59	B•E•C
E9	ZC5800E	ZETEX	shd	$V_A < 50 В; V_{F(I_F=1 мА)} < 0.41 В; I_S < 0.2 мкА; C_D < 2.0 нФ$	SOT23, SOD23	A • n.c. • K
E92	DTB123TK	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 500 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 100...600; f_T > 200 МГц; R_1 = 2.2 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
E94	DTB114TK	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 500 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 100...600; f_T > 200 МГц; R_1 = 10 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
E97	DTB163TK	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 500 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} > 100...600; f_T > 200 МГц$	SOT346, SC59	B•E•C
EA	BCW65A	ALLEG	npn	$V_{CEB} < 60 В; I_{CB} < 20 мА; h_{21} > 100...250; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
EA	BCW65A	CDIL	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EA	BCW65A	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EA	MMB24711	VISH	dz	$V_{F1(ZT)} = 50 \text{ мкА}; 25...28.4 \text{ В}; I_S < 0.01 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
EAs	BCW65A	SIEM	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...250; f_T = 170 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EB	BCW65B	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_{C20} < 20 \text{ нА}; h_{FE1} = 160...400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EB	BCW65B	CDIL	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 160...400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EB	BCW65B	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 160...400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EB	HSPM4810	HP	pin	$I_C < 1 \text{ А}; P_D < 250 \text{ мВт}; V_{BR} > 100 \text{ В}; R_{\theta C} < 3.0 \text{ Ом}; C_D < 0.40 \text{ нФ}; L_1 = 1.0 \text{ нГ}$	SOT23, SOD23	K-K-A
EB	MSC1022-B	MOT	pnip	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; f_T = 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EBAA	MAX6125EUR	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6 \text{ В}; I_{CC} < 130 \text{ мкА}; V_{OUT} = 2.5 \text{ В}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
EBs	BCW65B	SIEM	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 160...400; f_T = 170 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EC	2SC2732	REN	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} = 30; f_T > 700 \text{ МГц}$	SOT346, SCS59	B-E-C
EC	2SC4462	REN	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; h_{FE1} = 30; f_T > 700 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
EC	BCW65C	CDIL	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 250...630; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EC	BCW65C	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 250...630; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EC	MMB24712	VISH	dz	$V_{F1(ZT)} = 50 \text{ мкА}; 26...29.4 \text{ В}; I_S < 0.01 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
EC	MSC1022-C	MOT	pnip	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; f_T = 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
ECAA	MAX6141EUR	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6 \text{ В}; I_{CC} < 130 \text{ мкА}; V_{OUT} = 4.096 \text{ В}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
ECs	BCW65C	SIEM	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 250...630; f_T = 170 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
ED	MMB24713	VISH	dz	$V_{F1(ZT)} = 50 \text{ мкА}; 28...31.5 \text{ В}; I_S < 0.01 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
EDAA	MAX6145EUR	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6 \text{ В}; I_{CC} < 130 \text{ мкА}; V_{OUT} = 4.5 \text{ В}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
EDAA	MAX6330SUR	MAX	reg+ mrc	$V_{IN} = 2.78 \text{ В}; V_{OUT} = 3.0 \text{ В}; I_{OUT} > 50 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-SHUNT
EE	MMB24714	VISH	dz	$V_{F1(ZT)} = 50 \text{ мкА}; 31.4...34.7 \text{ В}; I_S < 0.01 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
EEAA	MAX6150EUR	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6 \text{ В}; I_{CC} < 130 \text{ мкА}; V_{OUT} = 5.0 \text{ В}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
EF	BCW66F	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 75 \text{ В}; I_{C20} < 20 \text{ нА}; h_{FE1} = 100...250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EF	BCW66F	CDIL	npn	$V_{CE0} = 75 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EF	BCW66F	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 75 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EF	MMB24715	VISH	dz	$V_{F1(ZT)} = 50 \text{ мкА}; 34.2...37.8 \text{ В}; I_S < 0.01 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
EFAA	MAX6520EUR	MAX	vref	$V_{IN} = 2.4...1.1 \text{ В}; TC_{VOUT} < 50 \text{ ppm/}^\circ\text{C}; V_{OUT} = 1.2 \text{ В}$	SOT23, SOD23	VIN-VOUT-GND
EFs	BCW66F	SIEM	npn	$V_{CE0} = 75 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...250; f_T > 170 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EG	BCW66G	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 75 \text{ В}; I_{C20} < 20 \text{ нА}; h_{FE1} = 160...400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EG	BCW66G	CDIL	npn	$V_{CE0} = 75 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 160...400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EG	BCW66G	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 75 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 160...400; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EG	BRA114ECM	REN	Dpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_{OUT} = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 30; 10 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT323, SC70	B-E-C
EG	BRA114EMP	REN	Dpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_{OUT} = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 30; 10 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EGs	BCW66G	SIEM	npn	$V_{CE0} = 75 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 160...400; f_T = 170 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EH	1SS365	SANYO	di	$V_S < 10 \text{ В}; I_S = 35 \text{ мА}; V_{F1(F)} = 10 \text{ мА}; < 0.58 \text{ В}; I_S < 10 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
EH	BCW66H	CDIL	npn	$V_{CE0} = 75 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 250...630; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EH	BCW66H	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 75 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 250...630; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EH	MMB24716	VISH	dz	$V_{F1(ZT)} = 50 \text{ мкА}; 37...41.0 \text{ В}; I_S < 0.01 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
EHA	MAX6326UR22	MAX	mrc	$V_{IN} = 2.2 \text{ В}; V_{D0} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
EHs	BCW66H	SIEM	npn	$V_{CE0} = 75 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 250...630; f_T > 170 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EIA	MAX6327UR22	MAX	mrc	$V_{IN} = 2.2 \text{ В}; V_{D0} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
EJ	MMB24717	VISH	dz	$V_{F1(ZT)} = 50 \text{ мкА}; 40.9...45.2 \text{ В}; I_S < 0.01 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
EJAA	MAX6328UR22	MAX	mrc	$V_{IN} = 2.2 \text{ В}; V_{D0} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
EK	BCX41	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 125 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 63; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
EKAA	MAX6330LUR	MAX	reg+ mrc	$V_{IN} = 4.63 \text{ В}; V_{OUT} = 5.0 \text{ В}; I_{OUT} > 50 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-SHUNT
EKs	BCX41	SIEM	npn	$V_{CE0} = 125 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 63; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
ELAA	MAX6331LUR	MAX	reg+ mrc	$V_{IN} = 4.63 \text{ В}; V_{OUT} = 5.0 \text{ В}; I_{OUT} > 50 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-SHUNT

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
EMAA	MAX6330TUR	MAX	рег+ mrc	$V_{TR}=3.06\text{ В}; V_{OUT}=3.3\text{ В}; I_{OUT}>50\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- SHUNT
EN	2SK3288	REN	nMOS	$V_{DS}=30\text{ В}; I_D=100\text{ мА}; P_D=400\text{ мВт}; R_{DS(on)}<7\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	G-S-D
EN	2SK3378	REN	nMOS	$V_{DS}=30\text{ В}; I_D=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; R_{DS(on)}<7\text{ Ом}$	SOT23,SC70	G-S-D
ENAA	MAX6331TUR	MAX	рег+ mrc	$V_{TR}=3.06\text{ В}; V_{OUT}=3.3\text{ В}; I_{OUT}>50\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- SHUNT
EO	KTC3265	KEC	npn	$V_{CEB}=35\text{ В}; I_C=800\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=100...200; f_T>120\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
EPAA	MAX6331SUR	MAX	рег+ mrc	$V_{TR}=2.78\text{ В}; V_{OUT}=3.0\text{ В}; I_{OUT}>50\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- SHUNT
ET	BCW65AR	SIEM	npn	$V_{CEB}=60\text{ В}; I_C=800\text{ мА}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21}=100...250; f_T=170\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	C-B-E
EU	BCW65BR	SIEM	npn	$V_{CEB}=60\text{ В}; I_C=800\text{ мА}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21}=160...400; f_T=170\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	C-B-E
EW	BCW65CR	SIEM	npn	$V_{CEB}=32\text{ В}; I_C=800\text{ мА}; h_{21}>240; f_T>100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	C-B-E
EWAA	MAX6326UR23	MAX	mrc	$V_{TR}=2.32\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST-V _{CC}
EX	BCW65FR	SIEM	npn	$V_{CEB}=45\text{ В}; I_C=800\text{ мА}; h_{21}>100; f_T>100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	C-B-E
EXAA	MAX6326UR24	MAX	mrc	$V_{TR}=2.4\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST-V _{CC}
EY	BCW65GR	SIEM	npn	$V_{CEB}=45\text{ В}; I_C=800\text{ мА}; h_{21}>160; f_T>100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	C-B-E
EY	KTC3265	KEC	npn	$V_{CEB}=35\text{ В}; I_C=800\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=160...320; f_T>120\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
EYAA	MAX6326UR25	MAX	mrc	$V_{TR}=2.5\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST-V _{CC}
EZ	BCW65HR	SIEM	npn	$V_{CEB}=45\text{ В}; I_C=800\text{ мА}; h_{21}>240; f_T>100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	C-B-E
EZAA	MAX6326UR26	MAX	mrc	$V_{TR}=2.63\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST-V _{CC}
F	IRLML6401	IR	pMOS	HEXFET; $V_{DS}=12\text{ В}; I_D=3.4\text{ А}; P_D=1.3\text{ Вт}; R_{DS(on)}<0.125\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	G-S-D
F	MRF92711	MOT	npn	$V_{CEB}=20\text{ В}; I_C=10\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; h_{21}=50...200; f_T=8\text{ ГГц}$	SOT323,SC70	
F0	H5MP3820	HP	pin	$I_E<1\text{ А}; V_{BE}>50\text{ В}; R_E<0.6\text{ Ом}; C_C<0.8\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
F02	DTD123TK	ROHM	Dnpn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=100...600; f_T>200\text{ МГц}; R_1=2.2\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
F03	DTB143TK	ROHM	Dnpn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=100...600; f_T>200\text{ МГц}; R_1=4.7\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
F04	DTD114TK	ROHM	Dnpn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=100...600; f_T>200\text{ МГц}; R_1=10\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
F04	DTD163TK	ROHM	Dnpn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=100...600; f_T>200\text{ МГц}$	SOT346,SC59	B-E-C
F1	H5MP3821	HP	pin	$I_E<1\text{ А}; V_{BE}>50\text{ В}; R_E<0.6\text{ Ом}; C_C<0.8\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	n.c.-A-K
F1	KST1009F1	SAMS	npn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=350\text{ мВт}; h_{21}=300...60; f_T>150\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
F1	MMBC1009F1	MOT	npn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}=300...60$	SOT23,SOD23	B-E-C
F1	MMB25236BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ мА})=7.13...7.88\text{ В}; I_S<3\text{ мкА}$	SOT523	A-n.c.-K
F11	DTB113EK	ROHM	Dnpn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=33; f_T>200\text{ МГц}; R_1/R_2=1/1\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
F12	DTB123EK	ROHM	Dnpn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=39; f_T>200\text{ МГц}; R_1/R_2=2.2/2.2\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
F13	DTB143EK	ROHM	Dnpn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=47; f_T>200\text{ МГц}; R_1/R_2=4.7/4.7\text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
F13	DTB143EK	ROHM	Dnpn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=47; f_T>200\text{ МГц}; R_1/R_2=4.7/4.7\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
F14	DTB114EK	ROHM	Dnpn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=56; f_T>200\text{ МГц}; R_1/R_2=10/10\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
F10	KSA1182	SAMS	npn	$V_{CEB}=35\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}=70...140; f_T>200\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
F1p	BFS18	PHIL	npn	$V_{CEB}=30\text{ В}; I_C=30\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; h_{21}=35...125; f_T=200\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
F1Y	KSA1182	SAMS	npn	$V_{CEB}=35\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}=120...240; f_T>200\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
F2	BFS19	SGS	npn	$V_{CEB}=30\text{ В}; I_C=30\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; h_{21}=65...225; f_T=260\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
F2	H5MP3822	HP	pin=2	$I_E<1\text{ А}; V_{BE}>50\text{ В}; R_E<0.6\text{ Ом}; C_C<0.8\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1A2
F2	KST1009F2	SAMS	npn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=350\text{ мВт}; h_{21}=40...80; f_T>150\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
F2	MMB25237BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ мА})=7.79...8.61\text{ В}; I_S<3\text{ мкА}$	SOT523	A-n.c.-K
F21	DTD113EK	ROHM	Dnpn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=33; f_T>200\text{ МГц}; R_1/R_2=1/1\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
F22	DTD123EK	ROHM	Dnpn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=39; f_T>200\text{ МГц}; R_1/R_2=2.2/2.2\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
F23	DTD143EK	ROHM	Dnpn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=47; f_T>200\text{ МГц}; R_1/R_2=4.7/4.7\text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
F23	DTD143EK	ROHM	Dnpn	$V_{CEB}=50\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=47; f_T>200\text{ МГц}; R_1/R_2=4.7/4.7\text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
F23	DTD143ES	ROHM	Dnpn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 47; f_T > 200 МГц;$ $R_{\theta J/P_2} = 4.7/4.7 К\Omega$	SOT23, SOD23	В•Е•С
F23	DTD143TK	ROHM	Dnpn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 200 МГц;$ $R_{\theta J} = 4.7 К\Omega$	SOT346, SC59	В•Е•С
F24	DTD114EK	ROHM	Dnpn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 56; f_T > 200 МГц; R_{\theta J/P_2} = 10/10 К\Omega$	SOT346, SC59	В•Е•С
F2p	BFS19	PHIL	npn	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 30 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 65...225; f_T = 260 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
F2l	BFS19	PHIL	npn	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 30 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 65...225; f_T = 260 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
F3	1SS193	TOSH	di	$V_{\beta} < 80 В; I_C < 100 мА; V_{\beta}(I_C = 100 мА) < 1.2 В; I_{\beta} < 0.5 мкА; t_{\text{вкл}} < 4 нс$	SOT346, SC59	А•н.с.•К
F3	2SC4399	SANYO	npn	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 60...120; f_T > 320 МГц$	SOT323, SC70	В•Е•С
F3	HSMF3823	HP	pin-2	$I_C < 1 А; V_{\text{вкл}} > 50 В; R_{\theta} < 0.6 \text{ Ом}; C_0 < 0.8 нФ$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
F3	KST1009F3	SAMS	npn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 50 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 60...120; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
F3	MMBC1009F3	MOT	npn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} = 60...120$	SOT23, SOD23	В•Е•С
F4	2SC4399	SANYO	npn	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 90...180; f_T > 320 МГц$	SOT323, SC70	В•Е•С
F4	BFS18R	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 110 мВт; h_{21} = 35; f_T = 200 МГц$	SOT23, SOD23	Е•В•С
F4	HSMF3824	HP	pin-2	$I_C < 1 А; V_{\text{вкл}} > 50 В; R_{\theta} < 0.6 \text{ Ом}; C_0 < 0.8 нФ$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
F4	KST1009F4	SAMS	npn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 50 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 90...180; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
F4	MMBZ5239BT	DIODS	dz	$V_{\beta}(I_{\text{тл}} = 20 мА) = 8.65...9.56 В; I_{\beta} < 3 мкА$	SOT523	А•н.с.•К
F5	1SS250	TOSH	di	$V_{\beta} < 200 В; I_C < 100 мА; V_{\beta}(I_C = 100 мА) < 1.2 В; I_{\beta} < 1.0 мкА; t_{\text{вкл}} < 60 нс$	SOT346, SC59	А•н.с.•К
F5	1SS370	TOSH	di	$V_{\beta} < 200 В; I_C < 100 мА; V_{\beta}(I_C = 100 мА) < 1.2 В; I_{\beta} < 60 нс$	SOT23, SC70	А•н.с.•К
F5	2SC4399	SANYO	npn	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 135...270; f_T > 320 МГц$	SOT323, SC70	В•Е•С
F5	BFS19R	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 225; f_T = 260 МГц$	SOT23, SOD23	Е•В•С
F5	KST1009F5	SAMS	npn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 50 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 135...270; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
F5	MMBZ5240BT	DIODS	dz	$V_{\beta}(I_{\text{тл}} = 20 мА) = 9.5...10.5 В; I_{\beta} < 3 мкА$	SOT523	А•н.с.•К
F52	DTB123YC	ROHM	Dnpn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 200 МГц;$ $R_{\theta J} = 2.2 К\Omega$	SOT23, SOD23	В•Е•С
F52	DTB123YK	ROHM	Dnpn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 56; f_T > 200 МГц;$ $R_{\theta J/P_2} = 2.2/10 К\Omega$	SOT346, SC59	В•Е•С
F62	DTD123YK	ROHM	Dnpn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 56; f_T > 200 МГц;$ $R_{\theta J/P_2} = 2.2/10 К\Omega$	SOT346, SC59	В•Е•С
F7	BAV99RWT1	ON	di-2	$V_{\beta} < 70 В; I_C < 215 мА; V_{\beta}(I_C = 150 мА) < 1.25 В; I_{\beta} < 2 мкА; t_{\text{вкл}} < 4 нс$	SOT323, SC70	A1•K1, A2•K2
F8	BF824W	PHIL	pinp	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 25 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 25; f_T > 400 МГц$	SOT323, SC70	В•Е•С
F8p	BF824	PHIL	pinp	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 25 мА; P_D = 250 мВт; f_T = 450$	SOT23, SOD23	В•Е•С
F8l	BF824	PHIL	pinp	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 25 мА; P_D = 250 мВт; f_T = 450$	SOT23, SOD23	В•Е•С
F9	1SS321	TOSH	shd-2	$V_{\beta} > 10 В; V_{\beta}(I_C = 50 мА) < 1.0 В; I_{\beta}(V_{\beta} = 10 В) < 0.5 мкА; C_0 < 4.5 нФ$	SOT346, SC59	A1•A2•K1, K2
F9	2SA1774	ON	pinp	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 120...560; f_T = 140 МГц$	SOT416, SC75A	В•Е•С
F92	DTB123TK	ROHM	Dnpn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 100...600; f_T > 200 МГц;$ $R_{\theta J} = 2.2 К\Omega$	SOT346, SC59	В•Е•С
F93	DTB143TK	ROHM	Dnpn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 100...600; f_T > 200 МГц;$ $R_{\theta J} = 4.7 К\Omega$	SOT346, SC59	В•Е•С
FA	2SC5851A	REN	npn	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 35...75; f_T = 230 МГц$	SOT323, SC70	В•Е•С
FA	HSMF4820	HP	pin	$I_C < 1 А; P_D < 250 мВт; V_{\text{вкл}} > 50 В; R_{\theta} < 0.6 \text{ Ом}; C_0 < 1.0 нФ; L_0 = 1.0 нГ$	SOT23, SOD23	А•А•К
FAAA	MAX6326UR27	MAX	mrc	$V_{\text{тл}} = 2.7 В; V_{\text{до}} = 1.2...5.5 В; I_{\text{сб}} < 1.75 мкА$	SOT23, SOD23	GND•RST•V _{CC}
FB	2SC5851B	REN	npn	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 60...120; f_T = 230 МГц$	SOT323, SC70	В•Е•С
FBAA	MAX6326UR28	MAX	mrc	$V_{\text{тл}} = 2.8 В; V_{\text{до}} = 1.2...5.5 В; I_{\text{сб}} < 1.75 мкА$	SOT23, SOD23	GND•RST•V _{CC}
FC	2SC5851C	REN	npn	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 100...200; f_T = 230 МГц$	SOT323, SC70	В•Е•С
FCAA	MAX6326UR29	MAX	mrc	$V_{\text{тл}} = 2.93 В; V_{\text{до}} = 1.2...5.5 В; I_{\text{сб}} < 1.75 мкА$	SOT23, SOD23	GND•RST•V _{CC}
FD	BCV26	SGS	dpnp	$V_{CBO} = 40 В; I_C = 500 мА; P_D = 360 мВт; h_{21} > 10000; f_T = 200 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
FDAA	MAX6326UR31	MAX	mrc	$V_{\text{тл}} = 3.08 В; V_{\text{до}} = 1.2...5.5 В; I_{\text{сб}} < 1.75 мкА$	SOT23, SOD23	GND•RST•V _{CC}
FDp	BCV26	PHIL	dpnp	$V_{CBO} = 40 В; I_C = 300 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 20000; f_T = 220 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
FDb	BCV26	INF	dpnp	$V_{CBO} = 40 В; I_C = 500 мА; P_D = 360 мВт; h_{21} > 10000; f_T = 200 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
FDl	BCV26	PHIL	dpnp	$V_{CBO} = 40 В; I_C = 300 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 20000; f_T = 220 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
FE	BCV46	SGS	dpnp	$V_{CBO} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} > 400; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
FEAA	MAX6326UR30	MAX	mrc	$V_{\text{тл}} = 3.0 В; V_{\text{до}} = 1.2...5.5 В; I_{\text{сб}} < 1.75 мкА$	SOT23, SOD23	GND•RST•V _{CC}

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
FEp	BCV46	PHIL	dnpn	$V_{CB0}=80\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; h_{21}>4000; f_T=220\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FES	BCV46	INF	dnpn	$V_{CB0}=80\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=360\text{ мВт}; h_{21}>4000; f_T=200\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FEI	BCV46	PHIL	dnpn	$V_{CB0}=80\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; h_{21}>4000; f_T=220\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FF	BCV27	TOSH	dnpn	$V_{CB0}=40\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21}>100; f_T>170\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FF	JDV3C11	SGS	var-2	$V_B<20\text{ В}; I_B<0.01\text{ мкА}; C_{1B}=65.8...74.2\text{ нФ}; C_{4.6B}=11.5...14.3$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
FFAA	MAX6327UR23	MAX	mrc	$V_{TR}=2.32\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND-RST•V _{CC}
FFMA	MAX6327UR31	MAX	mrc	$V_{TR}=3.08\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND-RST•V _{CC}
FFNA	MAX6327UR30	MAX	mrc	$V_{TR}=3.0\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND-RST•V _{CC}
FFp	BCV27	PHIL	dnpn	$V_{CB0}=40\text{ В}; I_C=300\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; h_{21}>20000; f_T=220\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FFs	BCV27	INF	dnpn	$V_{CB0}=40\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=360\text{ мВт}; h_{21}>10000; f_T=170\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FFt	BCV27	PHIL	dnpn	$V_{CB0}=40\text{ В}; I_C=300\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; h_{21}>20000; f_T=220\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FG	BRC114ECM	REN	Dnpn	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>30; 10\text{ кВ}/10\text{ к}$	SOT323,SC70	B•E•C
FG	BRC114EMP	REN	Dnpn	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>30; 10\text{ кВ}/10\text{ к}$	SOT323,SOD23	B•E•C
FGAA	MAX6327UR24	MAX	mrc	$V_{TR}=2.4\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND-RST•V _{CC}
FGp	BCV47	PHIL	dnpn	$V_{CB0}=80\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; h_{21}>4000; f_T=220\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FGs	BCV47	INF	dnpn	$V_{CB0}=80\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=360\text{ мВт}; h_{21}>4000; f_T=170\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FGt	BCV47	PHIL	dnpn	$V_{CB0}=80\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; h_{21}>4000; f_T=220\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FH	1SS366	SANYO	shd-2	$V_B=10\text{ В}; V_{I1}(I_B=10\text{ мА})<0.58\text{ В}; I_{E1}(V_B=10\text{ В})<10\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A1•K2•K1,A2
FH	1SS375	SANYO	shd-2	$V_B=10\text{ В}; V_{I1}(I_B=10\text{ мА})<0.58\text{ В}; I_{E1}(V_B=10\text{ В})<10\text{ мкА}$	SOT323,SC70	A1•K2•K1,A2
FHAA	MAX6327UR25	MAX	mrc	$V_{TR}=2.5\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND-RST•V _{CC}
FHs	BFN24	SIEM	npn	$V_{CB0}=250\text{ В}; I_C=200\text{ мА}; P_D=360\text{ мВт}; h_{21}>40; f_T=70\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FIAA	MAX6327UR26	MAX	mrc	$V_{TR}=2.63\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND-RST•V _{CC}
FJAA	MAX6327UR27	MAX	mrc	$V_{TR}=2.7\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND-RST•V _{CC}
FJs	BFN26	SIEM	npn	$V_{CB0}=300\text{ В}; I_C=200\text{ мА}; P_D=360\text{ мВт}; h_{21}>30; f_T=70\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FKAA	MAX6327UR28	MAX	mrc	$V_{TR}=2.8\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND-RST•V _{CC}
FKs	BFN25	SIEM	npn	$V_{CB0}=250\text{ В}; I_C=200\text{ мА}; P_D=360\text{ мВт}; h_{21}>40; f_T=100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FLAA	MAX6327UR29	MAX	mrc	$V_{TR}=2.93\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND-RST•V _{CC}
FLs	BFN27	SIEM	npn	$V_{CB0}=300\text{ В}; I_C=200\text{ мА}; P_D=360\text{ мВт}; h_{21}>30; f_T=100\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FO	2SC27160	TOSH	npn	$V_{CB0}=35\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100...140; f_T>80\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FOAA	MAX6328UR23	MAX	mrc	$V_{TR}=2.32\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND-RST•V _{CC}
FOAA	MAX6328UR24	MAX	mrc	$V_{TR}=2.4\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND-RST•V _{CC}
FQ	2SA1037AKQ	ROHM	npn	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=120...270; f_T>140\text{ МГц}$	SOT346,SC59	B•E•C
FQ	2SA1576AQ	ROHM	npn	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=120...270; f_T>140\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
FQ	2SA1774	ROHM	npn	$V_{CB0}=60\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=120...270; f_T>140\text{ МГц}$	SOT416,SC75A	B•E•C
FQ	2SA2029Q	ROHM	npn	$V_{CB0}=60\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}=120...270; f_T>140\text{ МГц}$	VMT3,VMD3	B•E•C
F-Q	2PA1576R	PHIL	npn	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=120...270; f_T>100\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
FOAA	MAX6328UR25	MAX	mrc	$V_{TR}=2.5\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND-RST•V _{CC}
FR	2SA1034R	PAN	npn	$V_{CB0}=35\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=180...360; f_T=200\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FR	2SA1037AKR	ROHM	npn	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=180...390; f_T>140\text{ МГц}$	SOT346,SC59	B•E•C
FR	2SA1531R	PAN	npn	$V_{CB0}=35\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}=180...360; f_T=80\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
FR	2SA1576AR	ROHM	npn	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=180...390; f_T>140\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
FR	2SA1774	ROHM	npn	$V_{CB0}=60\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=180...390; f_T>140\text{ МГц}$	SOT416,SC75A	B•E•C
FR	2SA2029R	ROHM	npn	$V_{CB0}=60\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}=180...390; f_T>140\text{ МГц}$	VMT3,VMD3	B•E•C
FR	2SC2716R	TOSH	npn	$V_{CB0}=35\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}=40...80; f_T>80\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
F-R	2PA1576R	PHIL	npn	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=180...390; f_T>100\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
FRAA	MAX6328UR26	MAX	mrc	$V_{TR}=2.63\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	GND-RST•V _{CC}
FS	2SA1034S	PAN	npn	$V_{CB0}=35\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=260...520; f_T>200\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
FS	2SA1037AKS	ROHM	npn	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=270...560; f_T>140\text{ МГц}$	SOT346,SC59	B•E•C
FS	2SA1531S	PAN	npn	$V_{CB0}=35\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}=260...520; f_T=80\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
FS	2SA1576AS	ROHM	npn	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=270...560; f_T>140\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
FS	2SA1774	ROHM	npn	$V_{CB0}=60\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=270...560; f_T>140\text{ МГц}$	SOT416,SC75A	B•E•C
FS	2SA2029S	ROHM	npn	$V_{CB0}=60\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}=270...560; f_T>140\text{ МГц}$	VMT3,VMD3	B•E•C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типонаимал	П	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
F-S	2PA1576S	PHIL	pnр	$V_{CEB}=50\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; I_{H1}=270...560; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
FS	2SC5890	REN	pnр	$V_{CEB}=20\text{ B}; I_C=75\text{ mA}; P_D=700\text{ мВт}; I_{H1}=120...200; f_T > 5.5\text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
FSAA	MAX6328UR27	MAX	mrc	$V_{TR}=2.7\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FT	2SA1034T	PAN	pnр	$V_{CEB}=35\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; I_{H1}=360...700; f_T=200\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
FT	2SA1531T	PAN	pnр	$V_{CEB}=35\text{ B}; I_C=50\text{ mA}; P_D=150\text{ мВт}; I_{H1}=360...700; f_T=80\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
FTAA	MAX6328UR28	MAX	mrc	$V_{TR}=2.8\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FIQ	2PA1576Q	PHIL	pnр	$V_{CEB}=50\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; I_{H1}=120...270; f_T=100\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
FIR	2PA1576R	PHIL	pnр	$V_{CEB}=50\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; I_{H1}=180...390; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
FIS	2PA1576S	PHIL	pnр	$V_{CEB}=50\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; I_{H1}=270...560; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
FUAA	MAX6328UR29	MAX	mrc	$V_{TR}=2.93\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FV	1SV248	SANYO	pin	$V_B > 50\text{ B}; I_C=50\text{ mA}; V_{F1}(I_C=50\text{ mA})=0.92\text{ B}; I_B < 0.1\text{ мА}$	SOT323, SC70	A-n.c.-K
FV	1SV250	SANYO	pin	$V_B > 50\text{ B}; I_C=50\text{ mA}; V_{F1}(I_C=50\text{ mA})=0.92\text{ B}; I_B < 0.1\text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
FVAA	MAX6328UR31	MAX	mrc	$V_{TR}=3.08\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FVAA	MAX6328UR30	MAX	mrc	$V_{TR}=3.0\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FY	2SC2716Y	TOSH	npn	$V_{CEB}=35\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; P_D=150\text{ мВт}; I_{H1}=120...240; f_T > 80\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
FZAP	MAX6012AEUR	MAX	vref	$V_{IN}=2.5...12.6\text{ B}; TC_{VOUT} < 20\text{ ppm}/^\circ\text{C}; V_{OUT}=1.247\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZAQ	MAX6025AEUR	MAX	vref	$V_{IN}=V_{OUT} \pm 0.2...12.6\text{ B}; TC_{VOUT} < 20\text{ ppm}/^\circ\text{C}; V_{OUT}=2.500\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZAR	MAX6041AEUR	MAX	vref	$V_{IN}=V_{OUT} \pm 0.2...12.6\text{ B}; TC_{VOUT} < 20\text{ ppm}/^\circ\text{C}; V_{OUT}=4.096\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZAS	MAX6045AEUR	MAX	vref	$V_{IN}=V_{OUT} \pm 0.2...12.6\text{ B}; TC_{VOUT} < 20\text{ ppm}/^\circ\text{C}; V_{OUT}=4.500\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZAT	MAX6050AEUR	MAX	vref	$V_{IN}=V_{OUT} \pm 0.2...12.6\text{ B}; TC_{VOUT} < 20\text{ ppm}/^\circ\text{C}; V_{OUT}=5.000\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZAU	MAX6021AEUR	MAX	vref	$V_{IN}=2.5...12.6\text{ B}; TC_{VOUT} < 20\text{ ppm}/^\circ\text{C}; V_{OUT}=2.048\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZAV	MAX6346UR33	MAX	mrc	$V_{TR}=3.3\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZAW	MAX6346UR34	MAX	mrc	$V_{TR}=3.4\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZAX	MAX6346UR35	MAX	mrc	$V_{TR}=3.5\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZAY	MAX6346UR36	MAX	mrc	$V_{TR}=3.6\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZAZ	MAX6346UR37	MAX	mrc	$V_{TR}=3.7\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBA	MAX6346UR38	MAX	mrc	$V_{TR}=3.8\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBB	MAX6346UR39	MAX	mrc	$V_{TR}=3.9\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBC	MAX6346UR40	MAX	mrc	$V_{TR}=4.0\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBD	MAX6346UR41	MAX	mrc	$V_{TR}=4.1\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBE	MAX6346UR42	MAX	mrc	$V_{TR}=4.2\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBF	MAX6346UR43	MAX	mrc	$V_{TR}=4.3\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBG	MAX6346UR44	MAX	mrc	$V_{TR}=4.38\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBH	MAX6346UR45	MAX	mrc	$V_{TR}=4.5\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBI	MAX6346UR46	MAX	mrc	$V_{TR}=4.63\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBJ	MAX6347UR33	MAX	mrc	$V_{TR}=3.3\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBK	MAX6347UR34	MAX	mrc	$V_{TR}=3.4\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBL	MAX6347UR35	MAX	mrc	$V_{TR}=3.5\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBM	MAX6347UR36	MAX	mrc	$V_{TR}=3.6\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBN	MAX6347UR37	MAX	mrc	$V_{TR}=3.7\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBO	MAX6347UR38	MAX	mrc	$V_{TR}=3.8\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBP	MAX6347UR39	MAX	mrc	$V_{TR}=3.9\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBQ	MAX6347UR40	MAX	mrc	$V_{TR}=4.0\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBR	MAX6347UR41	MAX	mrc	$V_{TR}=4.1\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBS	MAX6347UR42	MAX	mrc	$V_{TR}=4.2\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBT	MAX6347UR43	MAX	mrc	$V_{TR}=4.3\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBU	MAX6347UR44	MAX	mrc	$V_{TR}=4.38\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBV	MAX6347UR45	MAX	mrc	$V_{TR}=4.5\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBW	MAX6347UR46	MAX	mrc	$V_{TR}=4.6\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBX	MAX6348UR33	MAX	mrc	$V_{TR}=3.3\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBY	MAX6348UR34	MAX	mrc	$V_{TR}=3.4\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZBZ	MAX6348UR35	MAX	mrc	$V_{TR}=3.5\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3
VMD3



SOT416
SOT523

SOT323
SOT346

SOT23-3
SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
FZCA	MAX6348UR36	MAX	mrc	$V_{TR}=3.6\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCB	MAX6348UR37	MAX	mrc	$V_{TR}=3.7\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCC	MAX6348UR38	MAX	mrc	$V_{TR}=3.8\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCD	MAX6348UR39	MAX	mrc	$V_{TR}=3.9\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCE	MAX6348UR40	MAX	mrc	$V_{TR}=4.0\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCF	MAX6348UR41	MAX	mrc	$V_{TR}=4.1\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCG	MAX6348UR42	MAX	mrc	$V_{TR}=4.2\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCH	MAX6348UR43	MAX	mrc	$V_{TR}=4.3\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCI	MAX6348UR44	MAX	mrc	$V_{TR}=4.38\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCJ	MAX6348UR45	MAX	mrc	$V_{TR}=4.5\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCK	MAX6348UR46	MAX	mrc	$V_{TR}=4.6\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<1.75\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCL	MAX6332UR16D3	MAX	mrc	$V_{TR}=1.6\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCM	MAX6332UR18D3	MAX	mrc	$V_{TR}=1.8\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCN	MAX6332UR22D3	MAX	mrc	$V_{TR}=2.2\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCO	MAX6333UR16D3	MAX	mrc	$V_{TR}=1.6\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCP	MAX6333UR18D3	MAX	mrc	$V_{TR}=1.8\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCQ	MAX6333UR20D3	MAX	mrc	$V_{TR}=2.0\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCR	MAX6333UR22D3	MAX	mrc	$V_{TR}=2.2\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCS	MAX6333UR23D3	MAX	mrc	$V_{TR}=2.3\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCT	MAX6334UR16D3	MAX	mrc	$V_{TR}=1.6\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCU	MAX6334UR18D3	MAX	mrc	$V_{TR}=1.8\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCV	MAX6334UR22D3	MAX	mrc	$V_{TR}=2.2\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZCW	MAX6001EUR	MAX	vref	$V_{IN}=2.5...12.6\text{ В}; I_{OUT}=±400\text{ мА}; V_{OUT}=1.250\text{ В}$	SOT23,SOD23	IN-OUT-GND
FZCW	MAZ6001UR	MAX	vref	$V_{OUT}=1.250\text{ В}$	SOT23,SOD23	+++n.c.
FZCX	MAX6002EUR	MAX	vref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ В}; I_{OUT}=±400\text{ мА}; V_{OUT}=2.500\text{ В}$	SOT23,SOD23	IN-OUT-GND
FZCX	MAZ6002UR	MAX	vref	$V_{OUT}=2.500\text{ В}$	SOT23,SOD23	+++n.c.
FZCY	MAX6004EUR	MAX	vref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ В}; I_{OUT}=±400\text{ мА}; V_{OUT}=4.096\text{ В}$	SOT23,SOD23	IN-OUT-GND
FZCY	MAZ6004UR	MAX	vref	$V_{OUT}=4.096\text{ В}$	SOT23,SOD23	+++n.c.
FZCZ	MAX6005EUR	MAX	vref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ В}; I_{OUT}=±400\text{ мА}; V_{OUT}=5.000\text{ В}$	SOT23,SOD23	IN-OUT-GND
FZCZ	MAZ6005UR	MAX	vref	$V_{OUT}=5.000\text{ В}$	SOT23,SOD23	+++n.c.
FZDA	MAX6012BEUR	MAX	vref	$V_{IN}=2.5...12.6\text{ В}; TC_{VOUT}<30\text{ ppm/}^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=1.247\text{ В}$	SOT23,SOD23	IN-OUT-GND
FZDB	MAX6025BEUR	MAX	vref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ В}; TC_{VOUT}<30\text{ ppm/}^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=2.500\text{ В}$	SOT23,SOD23	IN-OUT-GND
FZDC	MAX6041BEUR	MAX	vref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ В}; TC_{VOUT}<30\text{ ppm/}^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=4.096\text{ В}$	SOT23,SOD23	IN-OUT-GND
FZDD	MAX6045BEUR	MAX	vref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ В}; TC_{VOUT}<30\text{ ppm/}^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=4.500\text{ В}$	SOT23,SOD23	IN-OUT-GND
FZDE	MAX6050BEUR	MAX	vref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ В}; TC_{VOUT}<30\text{ ppm/}^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=5.000\text{ В}$	SOT23,SOD23	IN-OUT-GND
FZDF	MAX6021BEUR	MAX	vref	$V_{IN}=2.5...12.6\text{ В}; TC_{VOUT}<30\text{ ppm/}^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=2.048\text{ В}$	SOT23,SOD23	IN-OUT-GND
FZDK	MAX6003EUR	MAX	vref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ В}; I_{OUT}=±400\text{ мА}; V_{OUT}=3.000\text{ В}$	SOT23,SOD23	IN-OUT-GND
FZDK	MAZ6003UR	MAX	vref	$V_{OUT}=3.000\text{ В}$	SOT23,SOD23	+++n.c.
FZDL	MAX6332UR20D3	MAX	mrc	$V_{TR}=2.0\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZDM	MAX6332UR23D3	MAX	mrc	$V_{TR}=2.3\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZDN	MAX6334UR20D3	MAX	mrc	$V_{TR}=2.0\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZDO	MAX6334UR23D3	MAX	mrc	$V_{TR}=2.3\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}
FZDP	MAX6806UR46	MAX	vd	$V_{TR}=4.6\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<80\text{ мА}$	SOT23,SOD23	RST-GND- V_{CC}
FZDQ	MAX6806UR26	MAX	vd	$V_{TR}=2.6\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<80\text{ мА}$	SOT23,SOD23	RST-GND- V_{CC}
FZDR	MAX6806UR63	MAX	vd	$V_{TR}=2.3\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<80\text{ мА}$	SOT23,SOD23	RST-GND- V_{CC}
FZDS	MAX6807UR46	MAX	vd	$V_{TR}=4.6\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<80\text{ мА}$	SOT23,SOD23	RST-GND- V_{CC}
FZDT	MAX6807UR26	MAX	vd	$V_{TR}=2.6\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<80\text{ мА}$	SOT23,SOD23	RST-GND- V_{CC}
FZDU	MAX6808UR46	MAX	vd	$V_{TR}=4.6\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<80\text{ мА}$	SOT23,SOD23	RST-GND- V_{CC}
FZDV	MAX6808UR26	MAX	vd	$V_{TR}=2.6\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<80\text{ мА}$	SOT23,SOD23	RST-GND- V_{CC}
FZDW	MAX6030AEUR	MAX	vref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ В}; TC_{VOUT}<20\text{ ppm/}^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=3.000\text{ В}$	SOT23,SOD23	IN-OUT-GND
FZDX	MAX6030BEUR	MAX	vref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ В}; TC_{VOUT}<30\text{ ppm/}^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=3.000\text{ В}$	SOT23,SOD23	IN-OUT-GND
FZDY	MAX6334UR17D3	MAX	mrc	$V_{TR}=1.7\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<7\text{ мА}$	SOT23,SOD23	GND-RST- V_{CC}



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
FZEA	MAX6333UR25D3	MAX	mrc	$V_{TH}=2.5\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC}<7\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZEB	LM4041AIM3-1.2	MAX	wref	$V_{OUT}=1.225\text{ B}; \text{ACC}=0.1\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEC	LM4041BIM3-1.2	MAX	wref	$V_{OUT}=1.225\text{ B}; \text{ACC}=0.2\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZED	LM4041CIM3-1.2	MAX	wref	$V_{OUT}=1.225\text{ B}; \text{ACC}=0.5\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEE	LM4041DIM3-1.2	MAX	wref	$V_{OUT}=1.225\text{ B}; \text{ACC}=1.0\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEF	LM4040AIM3-2.1	MAX	wref	$V_{OUT}=2.048\text{ B}; \text{ACC}=0.1\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEG	LM4040BIM3-2.1	MAX	wref	$V_{OUT}=2.048\text{ B}; \text{ACC}=0.2\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEH	LM4040CIM3-2.1	MAX	wref	$V_{OUT}=2.048\text{ B}; \text{ACC}=0.5\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEI	LM4040DIM3-2.1	MAX	wref	$V_{OUT}=2.048\text{ B}; \text{ACC}=1.0\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEJ	LM4040AIM3-2.5	MAX	wref	$V_{OUT}=2.500\text{ B}; \text{ACC}=0.1\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEK	LM4040BIM3-2.5	MAX	wref	$V_{OUT}=2.500\text{ B}; \text{ACC}=0.2\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEL	LM4040CIM3-2.5	MAX	wref	$V_{OUT}=2.500\text{ B}; \text{ACC}=0.5\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEM	LM4040DIM3-2.5	MAX	wref	$V_{OUT}=2.500\text{ B}; \text{ACC}=1.0\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEN	LM4040AIM3-3.0	MAX	wref	$V_{OUT}=3.000\text{ B}; \text{ACC}=0.1\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEO	LM4040BIM3-3.0	MAX	wref	$V_{OUT}=3.000\text{ B}; \text{ACC}=0.2\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEP	LM4040CIM3-3.0	MAX	wref	$V_{OUT}=3.000\text{ B}; \text{ACC}=0.5\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEQ	LM4040DIM3-3.0	MAX	wref	$V_{OUT}=3.000\text{ B}; \text{ACC}=1.0\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZER	LM4040AIM3-4.1	MAX	wref	$V_{OUT}=4.096\text{ B}; \text{ACC}=0.1\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZES	LM4040BIM3-4.1	MAX	wref	$V_{OUT}=4.096\text{ B}; \text{ACC}=0.2\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZET	LM4040CIM3-4.1	MAX	wref	$V_{OUT}=4.096\text{ B}; \text{ACC}=0.5\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEU	LM4040DIM3-4.1	MAX	wref	$V_{OUT}=4.096\text{ B}; \text{ACC}=1.0\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEV	LM4040AIM3-5.0	MAX	wref	$V_{OUT}=5.000\text{ B}; \text{ACC}=0.1\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEW	LM4040BIM3-5.0	MAX	wref	$V_{OUT}=5.000\text{ B}; \text{ACC}=0.2\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEX	LM4040CIM3-5.0	MAX	wref	$V_{OUT}=5.000\text{ B}; \text{ACC}=0.5\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEY	LM4040DIM3-5.0	MAX	wref	$V_{OUT}=5.000\text{ B}; \text{ACC}=1.0\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZEZ	MAZ803LUR	MAX	mrc	$V_{TH}=5.0\text{ B}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZFA	MAZ803MUR	MAX	mrc	$V_{TH}=5.0\text{ B}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZFB	MAZ803TUR	MAX	mrc	$V_{TH}=3.3\text{ B}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZFC	MAZ803SUR	MAX	mrc	$V_{TH}=3.3\text{ B}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZFD	MAZ803RUR	MAX	mrc	$V_{TH}=3.0\text{ B}$	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZFL	MAX6808UR32	MAX	vd	$V_{TH}=3.2\text{ B}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ B}; I_{CC}<80\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST-GND-V _{CC}
FZFM	MAX6066AUR	MAX	wref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ B}; TC_{VOUT}<20\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=2.500\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZFN	MAX6066BUR	MAX	wref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ B}; TC_{VOUT}<30\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=2.500\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZFP	MAX6061AUR	MAX	wref	$V_{IN}=2.5...12.6\text{ B}; TC_{VOUT}<20\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=1.248\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZFQ	MAX6061BUR	MAX	wref	$V_{IN}=2.5...12.6\text{ B}; TC_{VOUT}<30\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=1.248\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZFS	MAX6067AUR	MAX	wref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ B}; TC_{VOUT}<20\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=4.500\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZFT	MAX6067BUR	MAX	wref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ B}; TC_{VOUT}<30\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=4.500\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZFV	MAX6063AUR	MAX	wref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ B}; TC_{VOUT}<20\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=3.000\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZFW	MAX6063BUR	MAX	wref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ B}; TC_{VOUT}<30\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=3.000\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZFY	MAX6062AUR	MAX	wref	$V_{IN}=2.5...12.6\text{ B}; R[\text{-}33\text{C}] TC_{VOUT}<20\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=2.048\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZFZ	MAX6062BUR	MAX	wref	$V_{IN}=2.5...12.6\text{ B}; TC_{VOUT}<30\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=2.048\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZGB	MAX6064AUR	MAX	wref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ B}; TC_{VOUT}<20\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=4.096\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZGC	MAX6064BUR	MAX	wref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ B}; TC_{VOUT}<30\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=4.096\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZGE	MAX6065AUR	MAX	wref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ B}; TC_{VOUT}<20\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=5.000\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZGF	MAX6065BUR	MAX	wref	$V_{IN}=V_{OUT}+0.2...12.6\text{ B}; TC_{VOUT}<30\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}; V_{OUT}=5.000\text{ B}$	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZGH	MAX6066AUR	MAX	wref	$\text{ACC}=0.2\%; I_{OUT}\pm 400\text{ мкА}; V_{OUT}=1.25\text{ B}$	SOT23, SOD23	OUT-GND-1.c.
FZGJ	MAX6066BUR	MAX	wref	$V_{OUT}=1.250\text{ B}; \text{ACC}=0.2\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZGI	MAX6066BUR	MAX	wref	$\text{ACC}=0.5\%; I_{OUT}\pm 400\text{ мкА}; V_{OUT}=1.25\text{ B}$	SOT23, SOD23	OUT-GND-1.c.
FZGK	MAX6066BUR	MAX	wref	$V_{OUT}=1.250\text{ B}; \text{ACC}=0.5\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZGJ	MAX6066CUR	MAX	wref	$V_{OUT}=1.250\text{ B}; \text{ACC}=1.0\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.
FZGK	MAX6070AUR	MAX	wref	$\text{ACC}=0.2\%; I_{OUT}\pm 400\text{ мкА}; V_{OUT}=2.048\text{ B}$	SOT23, SOD23	OUT-GND-1.c.
FZGK	MAX6070AUR	MAX	wref	$V_{OUT}=2.480\text{ B}; \text{ACC}=0.2\%$	SOT23, SOD23	+++n.c.

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
FZGL	MAX6007BEUR	MAX	vref	ACC-0.5%; I _{OUT} ±400 мкА; V _{OUT} -2.048 В	SOT23, SOD23	OUT-GND-i.c.
FZGL	MAZ6007BUR	MAX	vref	V _{OUT} -2.480 В; ACC-0.5%	SOT23, SOD23	***-n.c.
FZGM	MAZ6007CUR	MAX	vref	V _{OUT} -2.480 В; ACC-1.0%	SOT23, SOD23	***-n.c.
FZGN	MAX6008AEUR	MAX	vref	ACC-0.2%; I _{OUT} ±400 мкА; V _{OUT} -2.5 В	SOT23, SOD23	OUT-GND-i.c.
FZGN	MAZ6008AUR	MAX	vref	V _{OUT} -2.500 В; ACC-0.2%	SOT23, SOD23	***-n.c.
FZGO	MAX6008BEUR	MAX	vref	ACC-0.5%; I _{OUT} ±400 мкА; V _{OUT} -2.5 В	SOT23, SOD23	OUT-GND-i.c.
FZGO	MAZ6008BUR	MAX	vref	V _{OUT} -2.500 В; ACC-0.5%	SOT23, SOD23	***-n.c.
FZGP	MAZ6008CUR	MAX	vref	V _{OUT} -2.500 В; ACC-1.0%	SOT23, SOD23	***-n.c.
FZGQ	MAX6009AEUR	MAX	vref	ACC-0.2%; I _{OUT} ±400 мкА; V _{OUT} -3.0 В	SOT23, SOD23	OUT-GND-i.c.
FZGQ	MAZ6009AUR	MAX	vref	V _{OUT} -3.000 В; ACC-0.2%	SOT23, SOD23	***-n.c.
FZGR	MAX6009BEUR	MAX	vref	ACC-0.5%; I _{OUT} ±400 мкА; V _{OUT} -3.0 В	SOT23, SOD23	OUT-GND-i.c.
FZGR	MAZ6009BUR	MAX	vref	V _{OUT} -3.000 В; ACC-0.5%	SOT23, SOD23	***-n.c.
FZGS	MAZ6009CUR	MAX	vref	V _{OUT} -3.000 В; ACC-1.0%	SOT23, SOD23	***-n.c.
FZGT	MAX6101EUR	MAX	vref	V _{IN} -2.5...12.6 В; I _{CC} < 125 мкА; V _{OUT} -1.250 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZGU	MAX6102EUR	MAX	vref	V _{IN} -V _{OUT} +0.2...12.6 В; I _{CC} < 125 мкА; V _{OUT} -2.500 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZGV	MAX6103EUR	MAX	vref	V _{IN} -V _{OUT} +0.2...12.6 В; I _{CC} < 125 мкА; V _{OUT} -3.000 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZGW	MAX6104EUR	MAX	vref	V _{IN} -V _{OUT} +0.2...12.6 В; I _{CC} < 125 мкА; V _{OUT} -4.096 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZGX	MAX6105EUR	MAX	vref	V _{IN} -V _{OUT} +0.2...12.6 В; I _{CC} < 125 мкА; V _{OUT} -5.000 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZHA	MAX6334UR16D2	MAX	mrc	V _{TR} -1.6 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 7 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZHA	MAX6334UR24D1	MAX	mrc	V _{TR} -2.4 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 7 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZHC	MAX6375UR26	MAX	vd	V _{TR} -2.63 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHD	MAX6375UR22	MAX	vd	V _{TR} -2.20 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHE	MAX6375UR23	MAX	vd	V _{TR} -2.32 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHF	MAX6375UR29	MAX	vd	V _{TR} -2.93 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHG	MAX6375UR31	MAX	vd	V _{TR} -3.08 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHH	MAX6376UR22	MAX	vd	V _{TR} -2.20 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHI	MAX6376UR23	MAX	vd	V _{TR} -2.32 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHU	MAX6376UR26	MAX	vd	V _{TR} -2.63 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHK	MAX6376UR29	MAX	vd	V _{TR} -2.93 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHL	MAX6376UR31	MAX	vd	V _{TR} -3.08 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHM	MAX6377UR22	MAX	vd	V _{TR} -2.20 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHN	MAX6377UR23	MAX	vd	V _{TR} -2.32 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHO	MAX6377UR26	MAX	vd	V _{TR} -2.63 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHP	MAX6377UR29	MAX	vd	V _{TR} -2.93 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHQ	MAX6377UR31	MAX	vd	V _{TR} -3.08 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHR	MAX6377UR27	MAX	vd	V _{TR} -2.70 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHS	MAX6377UR24	MAX	vd	V _{TR} -2.40 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHT	MAX6377UR28	MAX	vd	V _{TR} -2.80 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHU	MAX6378UR44	MAX	vd	V _{TR} -4.38 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHV	MAX6378UR46	MAX	vd	V _{TR} -4.63 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHW	MAX6379UR44	MAX	vd	V _{TR} -4.38 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHX	MAX6379UR46	MAX	vd	V _{TR} -4.63 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHY	MAX6380UR44	MAX	vd	V _{TR} -4.38 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZHZ	MAX6380UR46	MAX	vd	V _{TR} -4.63 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZIA	MAX6380UR42	MAX	vd	V _{TR} -4.20 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 1.75 мкА	SOT23, SOD23	OUT-GND-V _{CC}
FZIB	MAX6068AEUR	MAX	vref	V _{IN} -V _{OUT} +0.2...12.6 В; TC _{ROUT} < 20 ppm/°C; V _{OUT} -1.800 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZIC	MAX6068BEUR	MAX	vref	V _{IN} -V _{OUT} +0.2...12.6 В; TC _{ROUT} < 30 ppm/°C; V _{OUT} -1.800 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZID	MAX6100EUR	MAX	vref	V _{IN} -2.5...12.6 В; I _{CC} < 125 мкА; V _{OUT} -1.800 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZIE	MAX6800UR26D3	MAX	mrc	V _{TR} -2.63 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 12 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZIF	MAX6800UR29D3	MAX	mrc	V _{TR} -2.93 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 12 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZIG	MAX6800UR31D3	MAX	mrc	V _{TR} -3.08 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 12 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZIH	MAX6800UR44D3	MAX	mrc	V _{TR} -4.38 В; V _{DD} -1.2...5.5 В; I _{CC} < 12 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
FZII	MAX6800UR46D3	MAX	mpc	V_{TH} : 4.63 В; V_{DD} : 1.2...5.5 В; I_{CC} : 12 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZIK	MAX6801UR26D3	MAX	mpc	V_{TH} : 2.63 В; V_{DD} : 1.2...5.5 В; I_{CC} : 12 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZIL	MAX6801UR29D2	MAX	mpc	V_{TH} : 2.93 В; V_{DD} : 1.2...5.5 В; I_{CC} : 12 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZIM	MAX6801UR29D3	MAX	mpc	V_{TH} : 2.93 В; V_{DD} : 1.2...5.5 В; I_{CC} : 12 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZIN	MAX6801UR31D3	MAX	mpc	V_{TH} : 3.08 В; V_{DD} : 1.2...5.5 В; I_{CC} : 12 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZIO	MAX6801UR44D3	MAX	mpc	V_{TH} : 4.38 В; V_{DD} : 1.2...5.5 В; I_{CC} : 12 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZIP	MAX6801UR46D3	MAX	mpc	V_{TH} : 4.63 В; V_{DD} : 1.2...5.5 В; I_{CC} : 12 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZIQ	MAX6802UR26D3	MAX	mpc	V_{TH} : 2.63 В; V_{DD} : 1.2...5.5 В; I_{CC} : 12 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZIS	MAX6802UR31D3	MAX	mpc	V_{TH} : 3.08 В; V_{DD} : 1.2...5.5 В; I_{CC} : 12 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZIT	MAX6802UR44D3	MAX	mpc	V_{TH} : 4.38 В; V_{DD} : 1.2...5.5 В; I_{CC} : 12 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZIU	MAX6802UR46D3	MAX	mpc	V_{TH} : 4.63 В; V_{DD} : 1.2...5.5 В; I_{CC} : 12 мкА	SOT23, SOD23	GND-RST-V _{CC}
FZJR	MAX6106EUR	MAX	wref	V_{IN} : 2.5...12.6 В; I_{CC} : <125 мкА; V_{OUT} : 2.048 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
FZMV	MAX16107EUR	MAX	wref	V_{IN} : V_{OUT} + 0.2...12.6 В; I_{CC} : <125 мкА; V_{OUT} : 4.500 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
G	IRLML2502	IR	nMOS	HEXFET; V_{DS} : 30 В; I_D : 3.4 А; P_D : 1.25 Вт; $R_{DS(on)}$: 0.08 Ом	SOT23, SOD23	G-S-D
G	MRF947AT1	MOT	nnp	V_{CBB} : 20 В; I_C : 50 мА; P_D : 188 мВт; h_{21} : 75...150; f_T : 8 ГГц	SOT323, SC70	B-E-C
G0	HSMP3890	HP	pin	I_C : <1 А; P_D : <250 мВт; V_{BR} : >100 В; $R_{\theta C}$: <2.5 Ом; C_D : <0.30 нФ	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
G0	HSMP389B	HP	pin	I_C : <1 А; V_{BR} : >100 В; $R_{\theta C}$: <2.5 Ом; CT <0.30 нФ	SOT23, SC70	A-n.c.-K
G08	DTD133HK	ROHM	Dnpnp	V_{CBB} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : >56; f_T : >200 МГц; R_1/R_2 : 3.3/10 кОм	SOT346, SC59	B-E-C
G1	BFS20	ZETEX	nnp	V_{CBB} : 30 В; I_C : 25 мА; P_D : 330 мВт; h_{21} : 40...85; f_T : 450 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
G1	MMBZ15551	MOT	pin	V_{CBB} : 160 В; I_C : 600 мА; P_D : 300 мВт; h_{21} : 80...250	SOT23, SOD23	B-E-C
G1	MMBZ5226BT	DIODS	dz	$V_F(I_{FZT}=20\text{ mA})$: 3.14...3.47 В; I_R : <25 мкА	SOT523	A-n.c.-K
G10	NSD50610	NS	pMOS	V_{DS} : 60 В; I_D : 120 мА; P_D : 360 мВт; $R_{DS(on)}$: <300 м	SOT23, SOD23	G-S-D
G11	DT81132K	ROHM	Dnpnp	V_{CBB} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 56; f_T : >200 МГц; R_1/R_2 : 1/10 кОм	SOT346, SC59	B-E-C
G17	MMBZ4617	VISH	dz	$V_F(I_{FZT}=250\text{ mA})$: 2.4 В; $Z_{VT}(I_{FZT}=250\text{ mA})$: <1400 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
G18	MMBZ4618	VISH	dz	$V_F(I_{FZT}=250\text{ mA})$: 2.7 В; $Z_{VT}(I_{FZT}=250\text{ mA})$: <1500 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
G19	MMBZ4619	VISH	dz	$V_F(I_{FZT}=250\text{ mA})$: 3.0 В; $Z_{VT}(I_{FZT}=250\text{ mA})$: <1600 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
G1E	BC847A	ROHM	nnp	V_{CBB} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 110...220; f_T : 200 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
G1F	BC847B	ROHM	nnp	V_{CBB} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 200...450; f_T : 200 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
G1G	BC847C	ROHM	nnp	V_{CBB} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 420...800; f_T : 200 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
G1J	BC848A	ROHM	nnp	V_{CBB} : 30 В; I_C : 100 мА; P_D : 250 мВт; h_{21} : 110...220; f_T : 200 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
G1K	BC848B	ROHM	nnp	V_{CBB} : 30 В; I_C : 100 мА; P_D : 250 мВт; h_{21} : 200...450; f_T : 200 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
G1K	BC848BW	ROHM	nnp	V_{CBB} : 30 В; I_C : 100 мА; P_D : 250 мВт; h_{21} : 200...450; f_T : 200 МГц	SOT323, SC70	B-E-C
G1L	BC848C	ROHM	nnp	V_{CBB} : 30 В; I_C : 100 мА; P_D : 250 мВт; h_{21} : 420...800; f_T : 200 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
G1p	BFS20	PHIL	nnp	V_{CBB} : 30 В; I_C : 25 мА; P_D : 250 мВт; h_{21} : 40; f_T : 450 МГц	SOT23, SOD23	B-E-C
G1t	HSMP3891	HP	pin	I_C : <1 А; P_D : <250 мВт; V_{BR} : >100 В; $R_{\theta C}$: <2.5 Ом; C_D : <0.30 нФ	SOT23, SOD23	n.c.-A-K
G2	HSMP3892	HP	pin-2	I_C : <1 А; P_D : <250 мВт; V_{BR} : >100 В; $R_{\theta C}$: <2.5 Ом; C_D : <0.30 нФ	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
G2	HSMP389C	HP	pin-2	I_C : <1 А; V_{BR} : >100 В; $R_{\theta C}$: <2.5 Ом; CT <0.30 нФ	SOT23, SC70	A1-K2-K1, A2
G2	MMBZ5227BT	DIODS	dz	$V_F(I_{FZT}=20\text{ mA})$: 3.42...3.78 В; I_R : <15 мкА	SOT523	A-n.c.-K
G20	MMBZ4620	VISH	dz	$V_F(I_{FZT}=250\text{ mA})$: 3.3 В; $Z_{VT}(I_{FZT}=250\text{ mA})$: <1650 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
G21	DTD1132K	ROHM	Dnpnp	V_{CBB} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 56; f_T : >200 МГц; R_1/R_2 : 1/10 кОм	SOT346, SC59	B-E-C
G21	DTD1132U	ROHM	Dnpnp	V_{CBB} : 50 В; I_C : 500 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 56; f_T : >200 МГц; R_1/R_2 : 1/10 кОм	SOT323, SC70	B-E-C
G21	MMBZ4621	VISH	dz	$V_F(I_{FZT}=250\text{ mA})$: 3.6 В; $Z_{VT}(I_{FZT}=250\text{ mA})$: <1700 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
G22	MMBZ4622	VISH	dz	$V_F(I_{FZT}=250\text{ mA})$: 3.9 В; $Z_{VT}(I_{FZT}=250\text{ mA})$: <1650 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
G23	MMBZ4623	VISH	dz	$V_F(I_{FZT}=250\text{ mA})$: 4.3 В; $Z_{VT}(I_{FZT}=250\text{ mA})$: <1600 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
G24	MMBZ4624	VISH	dz	$V_F(I_{FZT}=250\text{ mA})$: 4.7 В; $Z_{VT}(I_{FZT}=250\text{ mA})$: <1550 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
G25	MMBZ4625	VISH	dz	$V_F(I_{FZT}=250\text{ mA})$: 5.1 В; $Z_{VT}(I_{FZT}=250\text{ mA})$: <1500 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
G26	MMBZ4626	VISH	dz	$V_F(I_{FZT}=250\text{ mA})$: 5.6 В; $Z_{VT}(I_{FZT}=250\text{ mA})$: <1400 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
G27	MMBZ4627	VISH	dz	$V_F(I_{FZT}=250\text{ mA})$: 6.2 В; $Z_{VT}(I_{FZT}=250\text{ mA})$: <1200 Ом	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
G3	ISS196	TOSH	di	V_A : 80 В; I_C : <100 мА; $V_F(I_F=100\text{ mA})$: <1.2 В; I_R : 0.5 мкА; t_{RR} : 4 нс	SOT346, SC59	n.c.-A-K
G3	BAR63	SIEM	pin	V_A : 50 В; I_C : <100 мА; $V_F(I_F=100\text{ mA})$: <1.2 В; I_R : 0.05 мкА; C_D : <0.3 нФ	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
G3	HSMP3893	HP	pin-2	I_C : <1 А; P_D : <250 мВт; V_{BR} : >100 В; $R_{\theta C}$: <2.5 Ом; C_D : <0.30 нФ	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2

SOT490 TSM MFPKAL

VTM3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типонаимал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
G3	HSMР389Е	HP	pin-2	$I_F < 1 \text{ A}; V_{BR} > 100 \text{ B}; R_S < 2.5 \text{ Ом}; CT < 0.30 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	K1-K2-A1,A2
G3	MMBZ5228BT	DIODS	dz	$V_{I(HI)} = 20 \text{ mA}; I_F = 3.71...4.10 \text{ B}; I_S < 10 \text{ мкА}$	SOT523	A-n.c.-K
-G3	PMS15551	PHIL	npn	$V_{CES} = 180 \text{ B}; I_C = 600 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 80...250; f_T > 100...300 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
G3C	DTB122JK	ROHM	Dnpn	$V_{CES} = 50 \text{ B}; I_C = 500 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 47; f_T > 250 \text{ МГц}$ $R_1/R_2 = 0.22/4.7 \text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
G3E	BC857A	ROHM	npn	$V_{CES} = 50 \text{ B}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 125...250; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
G3F	BC857B	ROHM	npn	$V_{CES} = 50 \text{ B}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 220...475; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
G3FQ	2SA1037AKQLT1	LRC	npn	$V_{CES} = 50 \text{ B}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 120...270; f_T > 140 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
G3FR	2SA1037AKRLT1	LRC	npn	$V_{CES} = 50 \text{ B}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 180...390; f_T > 140 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
G3FS	2SA1037AKSLT1	LRC	npn	$V_{CES} = 50 \text{ B}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 270...560; f_T > 140 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
G3J	BC858A	ROHM	npn	$V_{CES} = 30 \text{ B}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 125...250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
G3K	BC858B	ROHM	npn	$V_{CES} = 30 \text{ B}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 310 \text{ мВт}; h_{21} = 200...450; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
G3K	BC858BW	ROHM	npn	$V_{CES} = 30 \text{ B}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 220...475; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
G3L	BC858C	ROHM	npn	$V_{CES} = 30 \text{ B}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 420...800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
G4	BAR6304	SIEM	pin-2	$V_A < 50 \text{ B}; I_F < 100 \text{ mA}; V_F(I_F = 100 \text{ mA}) < 1.2 \text{ B}; I_S < 0.05 \text{ мкА}; C_D < 0.3 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
G4	BFS20R	PHIL	npn	$V_{CES} = 30 \text{ B}; I_C = 25 \text{ mA}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 40; f_T > 450 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
G4	HSMР389А	HP	pin-2	$I_F < 1 \text{ A}; P_D < 250 \text{ мВт}; V_{BR} > 100 \text{ B}; R_S < 2.5 \text{ Ом}; C_T < 0.30 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
G4	HSMР389F	HP	pin-2	$I_F < 1 \text{ A}; V_{BR} > 100 \text{ B}; R_S < 2.5 \text{ Ом}; CT < 0.30 \text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1-A2-K1,K2
G4	MMBZ5239BT	DIODS	dz	$V_{I(HI)} = 20 \text{ mA}; I_F = 4.09...4.52 \text{ B}; I_S < 5 \text{ мкА}$	SOT523	A-n.c.-K
G4C	DTD122JK	ROHM	Dnpn	$V_{CES} = 50 \text{ B}; I_C = 500 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 47; f_T > 200 \text{ МГц}$ $R_1/R_2 = 0.22/4.7 \text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
G4C	DTD122JK	ROHM	Dnpn	$V_{CES} = 50 \text{ B}; I_C = 500 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 47; f_T > 200 \text{ МГц}$ $R_1/R_2 = 0.22/4.7 \text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
G4s	BAR63-04	INF	pin-2	$V_A < 50 \text{ B}; I_F < 100 \text{ mA}; V_F(I_F = 100 \text{ mA}) < 1.2 \text{ B}; I_S < 0.01 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
G4s	BAR63-04W	INF	pin-2	$V_A < 50 \text{ B}; I_F < 100 \text{ mA}; V_F(I_F = 100 \text{ mA}) < 1.2 \text{ B}; I_S < 0.01 \text{ мкА}$	SOT323,SC70	A1-K2-K1,A2
G5	BAR6305	SIEM	pin-2	$V_A < 50 \text{ B}; I_F < 100 \text{ mA}; V_F(I_F = 100 \text{ mA}) < 1.2 \text{ B}; I_S < 0.05 \text{ мкА}; C_D < 0.3 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,A2
G5	MMBZ5230BT	DIODS	dz	$V_{I(HI)} = 20 \text{ mA}; I_F = 4.47...4.94 \text{ B}; I_S < 5 \text{ мкА}$	SOT523	A-n.c.-K
G5s	BAR63-05	INF	pin-2	$V_A < 50 \text{ B}; I_F < 100 \text{ mA}; V_F(I_F = 100 \text{ mA}) < 1.2 \text{ B}; I_S < 0.01 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
G5s	BAR63-05W	INF	pin-2	$V_A < 50 \text{ B}; I_F < 100 \text{ mA}; V_F(I_F = 100 \text{ mA}) < 1.2 \text{ B}; I_S < 0.01 \text{ мкА}$	SOT323,SC70	A1-A2-K1,K2
G6	BAR6306	SIEM	pin-2	$V_A < 50 \text{ B}; I_F < 100 \text{ mA}; V_F(I_F = 100 \text{ mA}) < 1.2 \text{ B}; I_S < 0.05 \text{ мкА}; C_D < 0.3 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
G6A	BC817-16	TOSH	npn	$V_{CES} = 50 \text{ B}; I_C = 800 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 100...250; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
G6B	BC817-25	TOSH	npn	$V_{CES} = 50 \text{ B}; I_C = 800 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 160...400; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
G6s	BAR63-06	INF	pin-2	$V_A < 50 \text{ B}; I_F < 100 \text{ mA}; V_F(I_F = 100 \text{ mA}) < 1.2 \text{ B}; I_S < 0.01 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
G6s	BAR63-06W	INF	pin-2	$V_A < 50 \text{ B}; I_F < 100 \text{ mA}; V_F(I_F = 100 \text{ mA}) < 1.2 \text{ B}; I_S < 0.01 \text{ мкА}$	SOT323,SC70	K1-K2-A1,A2
G7	BFS579	VIS	npn	$V_{CES} = 20 \text{ B}; I_C = 25 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 20...90; f_T = 1750 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
G8	DTB133HK	ROHM	Dnpn	$V_{CES} = 50 \text{ B}; I_C = 500 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 56; f_T > 200 \text{ МГц}$ $R_1/R_2 = 3.3/10 \text{ кОм}$	SOT346,SC59	B-E-C
GA	HSMР4890	HP	pin	$I_F < 1 \text{ A}; P_D < 250 \text{ мВт}; V_{BR} > 100 \text{ B}; R_S < 2.5 \text{ Ом}; C_T < 0.375 \text{ нФ}; L_1 = 1.0 \text{ нГ}$	SOT23,SOD23	A-A-K
GAB	BCW60B	ROHM	npn	$V_{CES} = 32 \text{ B}; I_C = 200 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 180...310; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
GAC	BCW60C	ROHM	npn	$V_{CES} = 32 \text{ B}; I_C = 200 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 250...460; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
GAD	BCW60D	ROHM	npn	$V_{CES} = 32 \text{ B}; I_C = 200 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 380...630; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
GAH	BCX70H	ROHM	npn	$V_{CES} = 45 \text{ B}; I_C = 200 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 180...310; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
GAJ	BCX70J	ROHM	npn	$V_{CES} = 45 \text{ B}; I_C = 200 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 250...460; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
GAK	BCX70K	ROHM	npn	$V_{CES} = 45 \text{ B}; I_C = 200 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 380...630; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
GBB	BCW61B	ROHM	npn	$V_{CES} = 32 \text{ B}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 180...310; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
GBC	BCW61C	ROHM	npn	$V_{CES} = 32 \text{ B}; I_C = 200 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 250...460; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
GBG	BCX71G	ROHM	npn	$V_{CES} = 45 \text{ B}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 120...220; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
GBH	BCX71H	ROHM	npn	$V_{CES} = 45 \text{ B}; I_C = 200 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 180...310; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
GBJ	BCX71J	ROHM	npn	$V_{CES} = 45 \text{ B}; I_C = 200 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 250...460; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
GC	2SC2734	REN	npn	$V_{CES} = 20 \text{ B}; I_C = 50 \text{ mA}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 20...200; f_T > 1.4 \text{ ГГц}$	SOT346,SC59	B-E-C
GC	2SC4264	REN	npn	$V_{CES} = 20 \text{ B}; I_C = 50 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; h_{21} = 20...200; f_T > 1.4 \text{ ГГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
GC1	BCW29	ROHM	npn	$V_{CES} = 30 \text{ B}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 120...260$	SOT23,SOD23	B-E-C
GC2	BCW30	ROHM	npn	$V_{CES} = 30 \text{ B}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 215...500; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
GD1	BCW31	ROHM	npn	$V_{CE0} = 32 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 110 \dots 220; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GD2	BCW32	ROHM	npn	$V_{CE0} = 32 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 200 \dots 450; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GD3	BCW33	ROHM	npn	$V_{CE0} = 32 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 420 \dots 800; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GE	2SA1455KE	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 120 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 390 \dots 820; f_T > 140 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	В+Е-С
GEC	BCW65C	ROHM	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 250 \dots 630; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GEs	BFR35AP	SIEM	npn	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 280 \text{ мВт}; h_{21} = 40 \dots 200; f_T = 5000 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GFs	BFR92P	SIEM	npn	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 280 \text{ мВт}; h_{21} = 40 \dots 200; f_T = 5000 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GG	BFS79R	VIS	pnp	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; I_C = 25 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 20 \dots 90; f_T = 1750 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	Е+В-С
GG	BFR93P	SIEM	npn	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 50 \dots 200; f_T = 5500 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GG	BRA143ECM	REN	Dnpn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_{CM} = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 20; 4.7 \text{ к}\Omega / 4.7 \text{ к}$	SOT323, SC70	В+Е-С
GG	BRA143EMP	REN	Dnpn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_{CM} = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 20; 4.7 \text{ к}\Omega / 4.7 \text{ к}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GH1	BCW69	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 120 \dots 260; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GH2	BCW70	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 215 \dots 500; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GK1	BCW71	ROHM	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 120 \dots 220; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GK2	BCW72	ROHM	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 200 \dots 450; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GLP	MMB17010LT1	MOT	pnp	$V_{CE0} = 45 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 300$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GLP	MSD1010T1	ETL	pnp	$V_{CE0} = 45 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 300$	SOT346, SC59	В+Е-С
GMA	BFS17	ROHM	npn	$V_{CE0} = 25 \text{ В}; I_C = 25 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 25 \dots 150; f_T > 1000 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GR	2SA1455KR	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 180 \dots 390; f_T > 140 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	В+Е-С
GS	2SA1455KS	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 270 \dots 560; f_T > 140 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	В+Е-С
GT1	BC846AT	CNTRL	npn	$V_{CE0} = 80 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 110 \dots 220; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT523	В+Е-С
GT1	BCX17	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 45 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 100 \dots 600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GT2	BC846BT	CNTRL	npn	$V_{CE0} = 80 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 200 \dots 450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT523	В+Е-С
GT2	BCX18	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 100 \dots 600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GT3	BC847AT	CNTRL	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 110 \dots 220; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT523	В+Е-С
GT4	BC847BT	CNTRL	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 200 \dots 450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT523	В+Е-С
GT5	BC847CT	CNTRL	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 420 \dots 800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT523	В+Е-С
GU1	BCX19	ROHM	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 100 \dots 600; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GU2	BCX20	ROHM	npn	$V_{CE0} = 25 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 100 \dots 600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
GV	1SV249	SANYO	pin-2	$V_B > 50 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; V_{CE(sat)} = 0.92 \text{ В}; I_C < 0.1 \text{ мА}$	SOT323, SC70	A1-K2-K1, A2
GV	1SV251	SANYO	pin-2	$V_B > 50 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; V_{CE(sat)} = 0.92 \text{ В}; I_C < 0.1 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
H	MRF947BT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 188 \text{ мВт}; h_{21} = 100 \dots 200; f_T = 8 \text{ ГГц}$	SOT323, SC70	В+Е-С
H02	DTC323TK	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 100 \dots 600; f_T > 200 \text{ МГц}; R_{\theta} = 2.2 \text{ к}\Omega\text{М}$	SOT346, SC59	В+Е-С
H02	DTC323TU	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 100 \dots 600; f_T > 200 \text{ МГц}; R_{\theta} = 2.2 \text{ к}\Omega\text{М}$	SOT323, SC70	В+Е-С
H03	DTC343TK	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 100 \dots 600; f_T > 200 \text{ МГц}; R_{\theta} = 4.7 \text{ к}\Omega\text{М}$	SOT346, SC59	В+Е-С
H04	DTC314TK	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 100 \dots 600; f_T > 200 \text{ МГц}; R_{\theta} = 10 \text{ к}\Omega\text{М}$	SOT346, SC59	В+Е-С
H04	DTC314TU	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 100 \dots 600; f_T > 200 \text{ МГц}; R_{\theta} = 10 \text{ к}\Omega\text{М}$	SOT323, SC70	В+Е-С
H07	DTC363TK	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 100 \dots 600; f_T > 200 \text{ МГц}; R_{\theta} = 6.8 \text{ к}\Omega\text{М}$	SOT346, SC59	В+Е-С
H1	BCW69	ALLEG	pnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_{CB0} < 100 \text{ нА}; h_{21} = 120 \dots 260; V_{CE(sat)} < 0.3 \text{ В}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
H1	BCW69	CDIL	pnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 120 \dots 260; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
H1	BCW69	ZETEX	pnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 120 \dots 260; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
H1	MMBZ5241BT	DIODS	dz	$V_{D(z)} = 20 \text{ mA} = 10.45 \dots 11.55 \text{ В}; I_S < 2 \text{ мкА}$	SOT523	A-n.c.-K
H1	SST4416	SIL	nFET	$V_{DS} = 30 \text{ В}; P_D = 350 \text{ мВт}; I_{OSS} = 5 \dots 15 \text{ мА}; g_m = 4.5 \text{ мСМ}; R_{DS(on)} = 150 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
H10	KSC2755	SAMS	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 70 \dots 140; f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
H1p	BCW69	PHIL	pnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 120 \dots 260; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
H1R	KSC2755	SAMS	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 40 \dots 80; f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
H1t	BCW69	PHIL	pnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 120 \dots 260; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
H1Y	KSC2755	SAMS	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 120 \dots 240; f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В+Е-С
H2	BCW70	ALLEG	pnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_{CB0} < 100 \text{ нА}; h_{21} = 215 \dots 500; V_{CE(sat)} < 0.3 \text{ В}$	SOT23, SOD23	В+Е-С

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	БД	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
H2	BCW70	CDIL	npn	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 215...500; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H2	BCW70	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 215...500; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H2	MMBZ5242BT	DIODS	dz	$V_{R1} = 20 В; I_{R1} = 11.4...12.6 В; I_{R1} < 1 мкА$	SOT523	A-n.c.-K
H21	2SJA63A	NEC	pMOS	$V_{GS} = 30 В; I_D = 100 мА; P_D = 150 мВт; R_{DS(on)} < 23 Ом$	SOT323, SC70	G-S-D
H27	DTC363ЕК	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 600 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 200 МГц$ $R_{1}/R_{2} = 6.8, 6.8 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
H27	DTC363EU	ROHM	Dnnp	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 600 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 70; f_T > 200 МГц$ $R_{1}/R_{2} = 6.8, 6.8 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
H20	KSC2756	SAMS	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 90...180; f_T > 850 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H2p	BCW70	PHIL	npn	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 215...500; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H2R	KSC2756	SAMS	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 60...120; f_T > 850 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H21	BCW70	PHIL	npn	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 215...500; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H2Y	KSC2756	SAMS	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 120...240; f_T > 850 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H3	2SA956H3	NEC	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 80...130; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H3	BCW89	CDIL	npn	$V_{CEB} = 80 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 120...260; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H3	BCW89	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 80 В; I_C = 100 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 120...260; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H3	KDV153	KEC	bd	$V_{R1} = 20 В; I_{R1} = 10 мА; C2B = 15 нФ; C10 B = 5 нФ; R_G < 0.6 Ом$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
H3	MMBZ5243BT	DIODS	dz	$V_{R1} = 9.5 мА; I_{R1} = 12.35...13.65 В; I_{R1} < 0.5 мкА$	SOT523	A-n.c.-K
H31	BCW89R	PHIL	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_C = 100 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 120...260; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H30	KSC2757	SAMS	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 90...180; f_T > 1100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H3p	BCW89	PHIL	npn	$V_{CEB} = 80 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 120...260; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H3R	KSC2757R	SAMS	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 60...120; f_T > 1100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H3t	BCW89	PHIL	npn	$V_{CEB} = 80 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 120...260; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H3Y	KSC2757Y	SAMS	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 120...240; f_T > 1100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H4	2SA956H4	NEC	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 110...170; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H4	BCW69R	PHIL	npn	$V_{CEB} = 45 В; I_C = 100 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 120...260; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	E-B-C
H4	BCW69R	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 120...260; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H4	SST5484	SIL	nFET	$V_{DS} = 25 В; P_D = 350 мВт; I_{DSS} = 1.5 мА; g_F = 2 мСм$	SOT23, SOD23	D-S-G
H4Z	KSC2758	SAMS	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 20 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 60...240; f_T > 1000 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H5	2SA956H5	NEC	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 150...240; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H5	BCW70R	PHIL	npn	$V_{CEB} = 45 В; I_C = 100 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 215...500; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	E-B-C
H5	BCW70R	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 215...500; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H5	MMBZ5245BT	DIODS	dz	$V_{R1} = 8.5 мА; I_{R1} = 14.25...15.75 В; I_{R1} < 0.1 мкА$	SOT523	A-n.c.-K
H5	SST5485	SIL	nFET	$V_{DS} = 25 В; P_D = 350 мВт; I_{DSS} = 4...10 мА; g_F = 3.5 мСм$	SOT23, SOD23	D-S-G
H50	KSC2223	SAMS	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 20 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 60...120; f_T > 600 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H5R	KSC2223	SAMS	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 20 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 40...80; f_T > 600 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H5Y	KSC2223	SAMS	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 20 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 90...180; f_T > 600 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H6	2SA956H6	NEC	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 200...320; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H6	BCW89R	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 80 В; I_C = 100 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 120...260; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H6	BCW89R	PHIL	npn	$V_{CEB} = 80 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 120...260; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	C-B-E
H6	SST5486	SIL	nFET	$V_{DS} = 25 В; P_D = 350 мВт; I_{DSS} = 8...20 мА; g_F = 4 мСм$	SOT23, SOD23	D-S-G
H60	KSC2759	SAMS	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 60...120; f_T > 2000 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H6R	KSC2759	SAMS	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 40...80; f_T > 2000 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H6Y	KSC2759	SAMS	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 90...180; f_T > 2000 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H71	BCF70R	PHIL	npn	$V_{CEB} = 45 В; I_C = 100 мА; P_D = 350 мВт; h_{21} = 215...500; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	E-B-C
H7p	BCF70	PHIL	npn	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} = 215...500; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H8Z	KSC2734	SAMS	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 200...200; f_T > 3500 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
H9	1SS344	TOSH	shd	$V_{R1} = 20 В; V_{R1} = 500 мА < 0.55 В; I_{R1} = 20 В < 20 мкА; C_T < 120 пФ$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
H9Z	KSC3120	SAMS	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 40...200; f_T > 2400 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
HA	2SA1883	SANYO	npn	$V_{CEB} = 15 В; I_C = 200 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 50...140; f_T > 450 МГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
HA	2SC2804	TOSH	npn	$V_{CEB} = 25 В; I_C = 20 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 900 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
HA	2SD1464	REN	npn	$V_{CEB} = 180 В; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 60...120; f_T = 140 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
HAO	KSC3123	SAMS	nprn	$V_{CBO} = 30$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 90...180$; $f_T > 1400$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
HAR	KSC3123	SAMS	nprn	$V_{CBO} = 30$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 60...120$; $f_T > 1400$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
HAY	KSC3123	SAMS	nprn	$V_{CBO} = 30$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 120...240$; $f_T > 1400$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
HB	2SD1464	REN	nprn	$V_{CBO} = 180$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 1$ Вт; $h_{21} = 100...200$; $f_T > 140$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
HBs	BFN23	SIEM	nprn	$V_{CBO} = 250$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 360$ мВт; $h_{21} > 50$; $f_T = 100$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
HC	2SC2733	REN	nprn	$V_{CBO} = 30$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} > 60$; $f_T > 600$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
HC	2SC4463	REN	nprn	$V_{CBO} = 30$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 100$ мВт; $h_{21} > 60$; $f_T > 600$ МГц	SOT323, SC70	В·Е·С
HCs	BFN23	SIEM	pnpr	$V_{CBO} = 250$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 360$ мВт; $h_{21} > 50$; $f_T = 100$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
HE	2SC3906KE	ROHM	nprn	$V_{CBO} = 120$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 390...820$; $f_T > 140$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
HE	2SC4102E	ROHM	nprn	$V_{CBO} = 120$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 390...820$; $f_T > 140$ МГц	SOT323, SC70	В·Е·С
HG	BRC143ECM	REN	Dnprn	$V_{CE} = 50$ В; $I_{CM} = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} > 20$; 4.7 к/4,7 к	SOT323, SC70	В·Е·С
HG	BRC143EMP	REN	Dnprn	$V_{CE} = 50$ В; $I_{CM} = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} > 20$; 4.7 к/4,7 к	SOT23, SOD23	В·Е·С
HP	2SA1036K	ROHM	nprn	$V_{CBO} = 40$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 82...180$; $f_T > 200$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
HP	2SA1577P	pnpr	pnpr	$V_{CBO} = 40$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 82...180$; $f_T > 200$ МГц	SOT23, SC70	В·Е·С
HQ	2SA1036KQ	ROHM	pnpr	$V_{CBO} = 40$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 120...270$; $f_T > 200$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
HQ	2SA1577Q	ROHM	pnpr	$V_{CBO} = 40$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 120...270$; $f_T > 200$ МГц	SOT23, SC70	В·Е·С
HQ	2SC3928Q	IDC	nprn	$V_{CBO} = 50$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 120...270$; $f_T > 200$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
HR	2SA1035R	PAN	pnpr	$V_{CBO} = 55$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 180...360$; $f_T > 200$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
HR	2SA1036KR	ROHM	nprn	$V_{CBO} = 40$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 180...390$; $f_T > 200$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
HR	2SA1531AR	PAN	pnpr	$V_{CBO} = 55$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 180...360$; $f_T = 80$ МГц	SOT23, SC70	В·Е·С
HR	2SA1577R	ROHM	pnpr	$V_{CBO} = 40$ В; $I_C = 500$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 180...390$; $f_T > 200$ МГц	SOT23, SC70	В·Е·С
HR	2SC3906KR	ROHM	nprn	$V_{CBO} = 120$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 180...390$; $f_T > 140$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
HR	2SC3928R	IDC	nprn	$V_{CBO} = 50$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 180...390$; $f_T > 200$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
HR	2SC4102R	ROHM	nprn	$V_{CBO} = 120$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 180...390$; $f_T > 140$ МГц	SOT23, SC70	В·Е·С
HS	2SA1035S	PAN	pnpr	$V_{CBO} = 55$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 260...520$; $f_T = 200$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
HS	2SA1531AS	PAN	pnpr	$V_{CBO} = 55$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 260...520$; $f_T = 80$ МГц	SOT23, SC70	В·Е·С
HS	2SC3906KS	ROHM	nprn	$V_{CBO} = 120$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 270...560$; $f_T > 140$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
HS	2SC3928S	IDC	nprn	$V_{CBO} = 50$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 270...560$; $f_T > 200$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
HS	2SC4102S	ROHM	nprn	$V_{CBO} = 120$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 270...560$; $f_T > 140$ МГц	SOT23, SC70	В·Е·С
HT	2SA1035T	PAN	pnpr	$V_{CBO} = 55$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 360...700$; $f_T = 200$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
HT	2SA1531AT	PAN	pnpr	$V_{CBO} = 55$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 360...700$; $f_T = 80$ МГц	SOT23, SC70	В·Е·С
HT	2SC3928T	IDC	nprn	$V_{CBO} = 50$ В; $I_C = 200$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 390...820$; $f_T = 200$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
I	MRF947RT3	MOT	nprn	$V_{CBO} = 20$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 188$ мВт; $h_{21} > 50$; $f_T = 8000$ МГц	SOT23, SC70	Е·В·С
IO	SST110	SIL	nFET	$V_{DS} = 25$ В; $P_D = 350$ мВт; $I_{DSS} > 10$ мА; $R_{DS(on)} < 18$ Ом	SOT23, SOD23	Д·S·G
IO	SST108	SIL	nFET	$V_{DS} = 25$ В; $P_D = 350$ мВт; $I_{DSS} > 80$ мА; $R_{DS(on)} < 8$ Ом	SOT23, SOD23	Д·S·G
I9	1SS336	TOSH	di-2	$V_A = 80$ В; $I_C = 200$ мА; $V_{CE}(I_C = 200$ мА) < 1.2 В; $I_{C0} < 0.5$ мА; $I_{ES} < 20$ нС	SOT346, SC59	K1·K2·A1, A2
I9	SST109	SIL	nFET	$V_{DS} = 25$ В; $P_D = 350$ мВт; $I_{DSS} > 40$ мА; $R_{DS(on)} < 12$ Ом	SOT23, SOD23	Д·S·G
ID	2SC3127	REN	nprn	$V_{CBO} = 20$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 150$ мВт; $f_T > 3.5$ ГГц	SOT346, SC59	В·Е·С
IE	2SC3722KE	ROHM	nprn	$V_{CBO} = 120$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 390...820$; $f_T > 140$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
IGD	2SK1215D	REN	nMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_D = 30$ мА; $P_D = 100$ мВт; $g_F > 8$ мСм; $I_{DSS} = 4...8$ мА	SOT23, SC70	Д·G·S
IGD	2SK360D	REN	nMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_D = 30$ мА; $P_D = 150$ мВт; $g_F > 8$ мСм; $I_{DSS} = 4...8$ мА	SOT23, SOD23	Д·G·S
IGE	2SK1215E	REN	nMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_D = 30$ мА; $P_D = 100$ мВт; $g_F > 8$ мСм; $I_{DSS} = 6...10$ мА	SOT23, SC70	Д·G·S
IGE	2SK360E	REN	nMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_D = 30$ мА; $P_D = 150$ мВт; $g_F > 8$ мСм; $I_{DSS} = 6...10$ мА	SOT23, SOD23	Д·G·S
IGF	2SK1215F	REN	nMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_D = 30$ мА; $P_D = 100$ мВт; $g_F > 8$ мСм; $I_{DSS} = 8...12$ мА	SOT23, SC70	Д·G·S
IGF	2SK360F	REN	nMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_D = 30$ мА; $P_D = 150$ мВт; $g_F > 8$ мСм; $I_{DSS} = 8...12$ мА	SOT23, SOD23	Д·G·S
IJ	2SC3374	REN	nprn	$V_{CBO} = 20$ В; $I_C = 20$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 20...200$; $f_T > 400$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
IL	2SC3493	REN	nprn	$V_{CBO} = 15$ В; $I_C = 20$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 30...200$; $f_T > 700$ МГц	SOT346, SC59	В·Е·С
IL	2SC4263	REN	nprn	$V_{CBO} = 15$ В; $I_C = 20$ мА; $P_D = 100$ мВт; $h_{21} = 30...200$; $f_T > 700$ МГц	SOT23, SC70	В·Е·С
IO	KTA1298	KEC	pnpr	$V_{CBO} = 35$ В; $I_C = 800$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 100...200$; $f_T > 120$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С
IP	2SC3793	REN	nprn	$V_{CBO} = 20$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 150$ мВт; $h_{21} = 50...200$; $f_T > 1.4$ ГГц	SOT346, SC59	В·Е·С
IP	2SC4262	REN	nprn	$V_{CBO} = 20$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 100$ мВт; $h_{21} = 50...200$; $f_T > 1.4$ ГГц	SOT23, SC70	В·Е·С
IR	2SB792R	PAN	pnpr	$V_{CBO} = 150$ В; $I_C = 50$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} = 130...220$; $f_T > 200$ МГц	SOT23, SOD23	В·Е·С

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
IR54	2SC3722KR	ROHM	n/n	$V_{CEB} < 120 В; I_C < 50 mA; P_D < 200 мВт; h_{FE1} < 180...390; f_T > 140 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
IR54	BAT54	IR	shd	$V_R < 30 В; I_R < 200 mA; V_{F(I_F=30 mA)} < 500 мВ; C_D < 10 нФ; t_{RR} < 5 нс$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
IR54C	BAT54C	IR	shd-2	$V_R < 30 В; I_R < 200 mA; V_{F(I_F=30 mA)} < 500 мВ; C_D < 10 нФ; t_{RR} < 5 нс$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1,K2
IR54S	BAT54S	IR	shd-2	$V_R < 30 В; I_R < 200 mA; V_{F(I_F=30 mA)} < 500 мВ; C_D < 10 нФ; t_{RR} < 5 нс$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1,A2
IRD	2SA1484D	HIT	p/n	$V_{CEB} < 90 В; I_C < 100 mA; P_D < 150 мВт; h_{FE1} < 250...500$	SOT23, SOD23	B-E-C
IRE	2SA1484E	HIT	p/n	$V_{CEB} < 90 В; I_C < 100 mA; P_D < 150 мВт; h_{FE1} < 400...800$	SOT23, SOD23	B-E-C
IS	2SB792S	PAN	p/n	$V_{CEB} < 150 В; I_C < 50 mA; P_D < 200 мВт; h_{FE1} < 185...330; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
IS	2SC3513	REN	p/n	$V_{CEB} < 15 В; I_C < 50 mA; P_D < 150 мВт; h_{FE1} < 50...250; f_T > 4.5 ГГц$	SOT346, SC59	B-E-C
IS	2SC3722KS	ROHM	n/n	$V_{CEB} < 120 В; I_C < 50 mA; P_D < 200 мВт; h_{FE1} < 270...560; f_T > 140 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
IS	2SC4537	REN	n/n	$V_{CEB} < 15 В; I_C < 50 mA; P_D < 100 мВт; h_{FE1} < 50...250; f_T > 4.5 ГГц$	SOT323, SC70	B-E-C
IT	2SB792T	PAN	p/n	$V_{CEB} < 150 В; I_C < 50 mA; P_D < 200 мВт; h_{FE1} < 260...450; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
IY	KTA1298	KEC	p/n	$V_{CEB} < 35 В; I_C < 800 mA; P_D < 200 мВт; h_{FE1} < 160...320; f_T > 120 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
J0	HSM52840	HP	shd	$V_R > 25 В; V_{F(I_F=30 mA)} < 0.7 В; I_R(V_R=1 В) < 100 mA; C_T < 1.0 нФ; R_D < 12 Ом$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J01	SO2906R	SGS	p/n	$V_{CEB} < 40 В; I_C < 150 mA; P_D < 300 мВт; h_{FE1} < 40...120; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	E-B-C
J03	SO2907AR	SGS	p/n	$V_{CEB} < 60 В; I_C < 150 mA; P_D < 300 мВт; h_{FE1} < 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	E-B-C
J05	SO2907R	SGS	p/n	$V_{CEB} < 40 В; I_C < 200 mA; P_D < 300 мВт; h_{FE1} < 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	E-B-C
J06	SO2894R	SGS	p/n	$V_{CEB} < 12 В; I_C < 200 mA; P_D < 300 мВт; h_{FE1} < 40...150; f_T > 400 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
J1	BSS138L	MOT	nMOS	$V_{DS} < 50 В; I_D < 200 mA; P_D < 360 мВт; g_{fs} < 120 мСм; R_{DS(on)} < 6 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
J1	HSM52841	HP	shd	$V_R > 25 В; V_{F(I_F=30 mA)} < 0.7 В; I_R(V_R=1 В) < 100 mA; C_T < 1.0 нФ; R_D < 12 Ом$	SOT23, SOD23	n.c.-A-K
J1	MMBZ5248BT	DIODES	dz	$V_{F(I_F=7.8 mA)} < 15.2...16.8 В; I_R < 0.1 mA$	SOT523	A-n.c.-K
J12	SO2906AR	SGS	p/n	$V_{CEB} < 60 В; I_C < 150 mA; P_D < 300 мВт; h_{FE1} < 40...120; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	E-B-C
J1A	ZC830A	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 10 \pm 10\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 4.5...6; Q > 300$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J1B	ZC830B	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 10 \pm 5\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 4.5...6; Q > 300$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J1O	KSA1298	SAMS	p/n	$V_{CEB} < 30 В; I_C < 800 mA; P_D < 200 мВт; h_{FE1} < 100...200; f_T > 120 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
J1S	ZC830	ZETEX	var	$V_R < 25 В; I_C < 10 \pm 20\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 4.5...6; Q > 300$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J1Y	KSA1298	SAMS	p/n	$V_{CEB} < 30 В; I_C < 800 mA; P_D < 200 мВт; h_{FE1} < 160...320; f_T > 120 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
J2A	ZC833A	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 33 \pm 10\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5...6.5; Q > 200$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J2B	ZC833B	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 33 \pm 5\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5...6.5; Q > 200$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J2S	ZC833	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 33 \pm 20\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5...6.5; Q > 200$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J3	MMBZ5248BT	DIODES	dz	$V_{F(I_F=7.0 mA)} < 17.1...18.9 В; I_R < 0.1 mA$	SOT523	A-n.c.-K
J32	SO5400R	SGS	p/n	$V_{CEB} < 130 В; I_C < 600 mA; P_D < 200 мВт; h_{FE1} < 40...180; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	E-B-C
J33	SO5401R	SGS	p/n	$V_{CEB} < 160 В; I_C < 600 mA; P_D < 200 мВт; h_{FE1} < 60...240; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	E-B-C
J39	SO692R	SGS	p/n	$V_{CEB} < 300 В; I_C < 100 mA; P_D < 310 мВт; h_{FE1} < 40; f_T > 50 МГц$	SOT23, SOD23	E-B-C
J3A	ZC831A	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 15 \pm 10\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 4.5...6; Q > 300$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J3B	ZC831B	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 15 \pm 5\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 4.5...6; Q > 300$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J3D	MS811T1	MOT	p/n	$f_T > 0.1 ГГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
J3S	ZC831	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 15 \pm 20\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 4.5...6; Q > 300$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J4A	MBV109T1	MOT	var	$V_R > 30 В; I_F < 200 mA; C_{2B} < 26...32 нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5.0...6.5$	SOT323, SC70	A-n.c.-K
J4A	ZC832A	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 22 \pm 10\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5...6.5; Q > 200$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J4B	ZC832B	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 22 \pm 5\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5...6.5; Q > 200$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J4S	ZC832	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 22 \pm 20\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5...6.5; Q > 200$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J5	MMBZ5250BT	DIODES	dz	$V_{F(I_F=6.2 mA)} < 19.0...21.0 В; I_R < 0.1 mA$	SOT523	A-n.c.-K
J5A	ZC834A	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 47 \pm 10\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5...6.5; Q > 200$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J5B	ZC834B	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 47 \pm 5\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5...6.5; Q > 200$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J5S	ZC834	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 47 \pm 20\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5...6.5; Q > 200$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J6	M1MA174	MOT	di	$V_R < 100 В; I_R < 200 mA; V_{F(I_F=10 mA)} < 1 В; t_{RR} < 4 нс$	SOT323, SC70	A-n.c.-K
J6A	ZC835A	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 68 \pm 10\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5...6.5; Q > 100$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J6B	ZC835B	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 68 \pm 5\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5...6.5; Q > 100$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J6S	ZC835	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 68 \pm 20\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5...6.5; Q > 100$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J7A	ZC836A	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 100 \pm 10\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5...6.5; Q > 100$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J7B	ZC836B	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 100 \pm 5\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5...6.5; Q > 100$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
J7S	ZC836	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_{2B} < 100 \pm 20\% нФ; C_{2B}/C_{20B} < 5...6.5; Q > 100$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TSM
MFPK TSFP-3

VMT3
VMD3

Код	Типонаимал	ЗЕТ	Ф	Особенности	Корпус	1+2+3
J8	BCX71JR	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 45 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 250 \dots 460; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В · Е · С
J8	BCX71JR	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 250 \dots 460; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	С · В · Е
J9	1SS337	TOSH	di-2	$V_A = 80 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 200 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}; I_{B1} < 0.5 \text{ мкА}; C_{E1} = 20 \text{ нФ}$	SOT346, SC59	A1 · A2 · K1, K2
J9A	ZC829A	ZETEX	var	$V_A < 25 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; I_{B1} < 0.02 \text{ мкА}; C_{E2} = 7.38 \dots 9.02 \text{ нФ}; C_{E20} = 4.3 \dots 5.8$	SOT23, SOD23	A · н.с. · К
J9B	ZC829B	ZETEX	var	$V_A = 25 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; I_{B1} < 0.02 \text{ мкА}; C_{E2} = 7.79 \dots 8.61 \text{ нФ}; C_{E2} / C_{E20} = 4.3 \dots 5.8$	SOT23, SOD23	A · н.с. · К
JA	BAV70W	WTE	di-2	$V_A = 75 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 50 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; C_D < 2 \text{ нФ}; I_{B1} < 6 \text{ нС}$	SOT323, SC70	A1 · A2 · K1, K2
JA	BAV74	ALLEG	di-2	$I_C < 70 \text{ мА}; V_{BE1} > 50 \text{ В}; V_{E1}(I_C = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{B1} < 100 \text{ нА}; I_{B1} < 4.0 \text{ нС}; C_D < 2.0 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1 · A2 · K1, K2
JA	BAV74	ZETEX	di-2	$V_A < 50 \text{ В}; I_C < 150 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{B1} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ нФ}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1 · A2 · K1, K2
JA	BAV74	Nat	di-2	$V_A < 50 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 100 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_D < 2 \text{ нФ}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1 · A2 · K1, K2
JAp	BAV74	PHIL	di-2	$V_A < 50 \text{ В}; I_C < 215 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; C_D < 2.0 \text{ нФ}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1 · A2 · K1, K2
JAs	BAV74	SIEM	di-2	$V_A < 50 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{B1} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1 · A2 · K1, K2
JB	BAR74	ZETEX	di	$V_A < 50 \text{ В}; I_C < 150 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{B1} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A · н.с. · К
JC	2SC2735	REN	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	В · Е · С
JC	2SC4265	REN	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	В · Е · С
JC	BAL74	ZETEX	di	$V_A < 50 \text{ В}; I_C < 150 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{B1} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ нФ}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	н.с. · А · К
JC	BAL74W	PHIL	fd	$V_A < 75 \text{ В}; I_C < 175 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 50 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT323, SC70	н.с. · А · К
JC	BAW56W	PANJIT	di-2	$V_A = 75 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 10 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_D < 4 \text{ нФ}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT323, SC70	K1 · K2 · A1, A2
JCP	BAL74	PHIL	fd	$V_A < 50 \text{ В}; I_C < 215 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 50 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; C_D < 2 \text{ нФ}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	н.с. · А · К
JCs	BAL74	INF	di	$V_A < 50 \text{ В}; I_C < 250 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{B1} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 2 \text{ нФ}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	н.с. · А · К
JD	BAW56	VISH	di-2	$V_A = 70 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{B1} < 5.0 \text{ мкА}; C_D < 4.0 \text{ нФ}; I_{B1} < 6 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	K1 · K2 · A1, A2
JD	BAW56T	DIODS	di-2	$V_A = 85 \text{ В}; I_C < 155 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{B1} < 2 \text{ мкА}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT523	K1 · K2 · A1, A2
JE	BAV99	VISH	di-2	$V_A = 70 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{B1} < 5.0 \text{ мкА}; C_D < 4.0 \text{ нФ}; I_{B1} < 6 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1 · K2 · K1, A2
JE	BAV99	GS	di-2	$V_A = 70 \text{ В}; I_C < 250 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{B1} < 2 \text{ мкА}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1 · K2 · K1, A2
JE	BAV99	TSC	di-2	$V_A < 75 \text{ В}; I_C < 215 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{B1} < 2 \text{ мкА}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1 · K2 · K1, A2
JE	BAV99T	DIODS	di-2	$V_A = 85 \text{ В}; I_C < 155 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{B1} < 2 \text{ мкА}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT523	A1 · K2 · K1, A2
JF	BAL99	VISH	di	$V_A = 70 \text{ В}; I_C < 250 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 50 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{B1} < 2.5 \text{ мкА}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; I_{B1} < 6 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	н.с. · К · А
JF	BAL99	GS	di	$V_A < 70 \text{ В}; I_C < 250 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{B1} < 2 \text{ мкА}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	н.с. · К · А
JF	BAL99W	PHIL	di	$V_A < 70 \text{ В}; I_C < 150 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 50 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT323, SC70	н.с. · К · А
JFp	BAL99	PHIL	di	$V_A < 70 \text{ В}; I_C < 250 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 50 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; I_{B1} < 6 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	н.с. · К · А
JFs	BAL99	INF	di	$V_A < 70 \text{ В}; I_C < 250 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 50 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{B1} < 2.5 \text{ мкА}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; I_{B1} < 6 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	н.с. · К · А
JG	BAV99	WTE	di-2	$V_A = 75 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{B1} < 2 \text{ мкА}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1 · K2 · K1, A2
JG	BAV99	PANJIT	di-2	$V_A = 75 \text{ В}; I_C < 150 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 10 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1 · K2 · K1, A2
JG	BRA123ECM	REN	Dpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_{CM} = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 20; 2, 2 \text{ к} / 2, 2 \text{ к}$	SOT323, SC70	В · Е · С
JG	BRA123EMP	REN	Dpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_{CM} = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 20; 2, 2 \text{ к} / 2, 2 \text{ к}$	SOT23, SOD23	В · Е · С
JGs	BAR99	SIEM	di	$V_A < 70 \text{ В}; I_C < 250 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 50 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{B1} < 2.5 \text{ мкА}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; I_{B1} < 6 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	K · н.с. · А
JD	2SA1566D	REN	npn	$V_{CE0} = 120 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} = 250 \dots 500$	SOT23, SOD23	В · Е · С
JIE	2SA1566E	REN	npn	$V_{CE0} = 120 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} = 400 \dots 800$	SOT23, SOD23	В · Е · С
JJ	BAV70	VISH	di-2	$V_A = 70 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{B1} < 5.0 \text{ мкА}; C_D < 4.0 \text{ нФ}; I_{B1} < 6 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1 · A2 · K1, K2
JJ	BAV70T	DIODS	di-2	$V_A = 85 \text{ В}; I_C < 155 \text{ мА}; V_{E1}(I_C = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{B1} < 2 \text{ мкА}; I_{B1} < 4 \text{ нС}$	SOT523	A1 · A2 · K1, K2
JL	MRF949T1	MOT	npn	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 144 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT323, SC70	В · Е · С
JM	2SC2059KM	ROHM	npn	$V_{CE0} = 25 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} = 39 \dots 82; f_T > 500 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	В · Е · С
JM	2SC4099M	ROHM	npn	$V_{CE0} = 25 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} = 39 \dots 82; f_T > 500 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	В · Е · С
JM	2SC4649	ROHM	npn	$V_{CE0} = 25 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} = 39 \dots 82; f_T > 500 \text{ МГц}$	SOT416, SC75A	В · Е · С
JN	2SC2059KN	ROHM	npn	$V_{CE0} = 25 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} = 56 \dots 120; f_T > 500 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	В · Е · С
JN	2SC4099N	ROHM	npn	$V_{CE0} = 25 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} = 56 \dots 120; f_T > 500 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	В · Е · С
JN	2SC4649	ROHM	npn	$V_{CE0} = 25 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} = 56 \dots 120; f_T > 500 \text{ МГц}$	SOT416, SC75A	В · Е · С
JP	2SC2059KP	ROHM	npn	$V_{CE0} = 25 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} = 82 \dots 180; f_T > 500 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	В · Е · С

SOT490 TSM MFFPAK **TESM TSFP-3**

VMT3 VMD3  

SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
JP	2SC4099P	ROHM	npn	$V_{CEB} < 25 В; I_C < 20 мА; P_D < 150 мВт; h_{FE1} > 82...180; f_T > 500 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
JP	2SC4649	ROHM	npn	$V_{CEB} < 25 В; I_C < 20 мА; P_D < 150 мВт; h_{FE1} > 82...180; f_T > 500 МГц$	SOT416, SC75A	B•E•C
JPp	BAS19	PHIL	fd	$V_R < 100 В; I_R < 200 мА; V_{F1}(I_F = 100 мА) < 1.0 В; C_D < 5 пФ; t_{RR} < 50 нс$	SOT23, SOD23	A•n.c. •K
JPs	BAS19	INF	di	$V_R < 100 В; I_R < 250 мА; V_{F1}(I_F = 100 мА) < 1.0 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 5.0 пФ; t_{RR} < 50 нс$	SOT23, SOD23	A•n.c. •K
JRp	BAS20	PHIL	fd	$V_R < 150 В; I_R < 200 мА; V_{F1}(I_F = 100 мА) < 1.0 В; C_D < 5 пФ; t_{RR} < 50 нс$	SOT23, SOD23	A•n.c. •K
JRs	BAS20	INF	di	$V_R < 150 В; I_R < 250 мА; V_{F1}(I_F = 100 мА) < 1.0 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 5.0 пФ; t_{RR} < 50 нс$	SOT23, SOD23	A•n.c. •K
JS	BAS21	JGD	di	$V_R < 200 В; I_R < 200 мА; V_{F1}(I_F = 100 мА) < 1.0 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 1.5 пФ; t_{RR} < 50 нс$	SOT23, SOD23	A•n.c. •K
JS3	2SA1857	SANYO	npnp	$V_{CEB} < 15 В; I_C < 50 мА; P_D < 150 мВт; h_{FE1} > 60...120; f_T > 750 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
JS4	2SA1857	SANYO	npnp	$V_{CEB} < 15 В; I_C < 50 мА; P_D < 150 мВт; h_{FE1} > 90...180; f_T > 750 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
JS5	2SA1857	SANYO	npnp	$V_{CEB} < 15 В; I_C < 50 мА; P_D < 150 мВт; h_{FE1} > 135...270; f_T > 750 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
JSp	BAS21	PHIL	fd	$V_R < 200 В; I_R < 200 мА; V_{F1}(I_F = 100 мА) < 1.0 В; C_D < 5 пФ; t_{RR} < 50 нс$	SOT23, SOD23	A•n.c. •K
JSp	BAS21	INF	di	$V_R < 200 В; I_R < 250 мА; V_{F1}(I_F = 100 мА) < 1.0 В; I_R < 0.1 мкА; C_D < 5.0 пФ; t_{RR} < 50 нс$	SOT23, SOD23	A•n.c. •K
JV	1SV263	SANYO	pin	$V_R > 50 В; I_R < 50 мА; V_{F1}(I_F = 50 мА) < 0.95 В; I_R < 0.1 мкА$	SOT323, SC70	A•n.c. •K
JV	1SV266	SANYO	pin	$V_R > 50 В; I_R < 50 мА; V_{F1}(I_F = 50 мА) < 0.91 В; I_R < 0.1 мкА$	SOT23, SOD23	A•n.c. •K
JVp	BAS116	PHIL	di	$V_R < 75 В; I_R < 215 мА; V_{F1}(I_F = 10 мА) < 1.0 В; I_R(I_R = 75 В) < 5 мА; C_D < 2 пФ; t_{RR} < 3000 нс$	SOT23, SOD23	A•n.c. •K
JVs	BAS116	SIEM	di	$V_R < 75 В; I_R < 250 мА; V_{F1}(I_F = 50 мА) < 1.1 В; I_R < 5.0 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 3000 нс$	SOT23, SOD23	A•n.c. •K
JX	BAV170	MOT	di-2	$V_R < 80 В; I_R < 200 мА; V_{F1}(I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 0.005 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 3000 нс$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
JXp	BAV170	PHIL	di-2	$V_R < 75 В; I_R < 215 мА; V_{F1}(I_F = 10 мА) < 1.0 В; I_R(I_R = 75 В) < 5 мА; C_D < 2 пФ; t_{RR} < 3000 нс$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
JXs	BAV170	INF	di-2	$V_R < 80 В; I_R < 200 мА; V_{F1}(I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 0.005 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 3000 нс$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
JXt	BAV170	PHIL	di-2	$V_R < 75 В; I_R < 215 мА; V_{F1}(I_F = 10 мА) < 1.0 В; I_R(I_R = 75 В) < 5 мА; C_D < 2 пФ; t_{RR} < 3000 нс$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
JYp	BAV199	PHIL	di-2	$V_R < 75 В; I_R < 160 мА; V_{F1}(I_F = 10 мА) < 1.0 В; I_R(I_R = 75 В) < 5 мА; C_D < 2 пФ; t_{RR} < 3000 нс$	SOT23, SOD23	A1•K2•K1, A2
JYs	BAV199	INF	di-2	$V_R < 80 В; I_R < 200 мА; V_{F1}(I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 0.005 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 1500 нс$	SOT23, SOD23	A1•K2•K1, A2
JYs	BAV199F	INF	di-2	$V_R < 80 В; I_R < 200 мА; V_{F1}(I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 0.005 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 1500 нс$	TSFP-3, VESM	A1•K2•K1, A2
JZp	BAW156	PHIL	di-2	$V_R < 75 В; I_R < 160 мА; V_{F1}(I_F = 10 мА) < 1.0 В; I_R(I_R = 75 В) < 5 мА; C_D < 3 пФ; t_{RR} < 3000 нс$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
JZs	BAW156	SIEM	di-2	$V_R < 70 В; I_R < 200 мА; V_{F1}(I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_R < 0.005 мкА; C_D < 2.0 пФ; t_{RR} < 3000 нс$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
K	MRF917T1	MOT	npn	$V_{CEB} < 20 В; I_C < 60 мА; P_D < 222 мВт; h_{FE1} > 40...200; f_T > 6 ГГц$	SOT323, SC70	B•E•C
K0	HSMF3830	HP	pin	$I_B < 1 А; V_{RR} > 200 В; R_{DS} < 1.5 Ом; C_D < 0.3 пФ$	SOT23, SOD23	A•n.c. •K
K1	BCW71	ALLEG	npn	$V_{CEB} < 50 В; I_{Cmax} < 100 мА; h_{FE1} > 110...220; V_{CE(sat)} < 0.25 В$	SOT23, SOD23	B•E•C
K1	BCW71	CDIL	npn	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{FE1} > 110...220; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
K1	BCW71	SAMS	npn	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 350 мВт; h_{FE1} > 120...220; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
K1	BCW71	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 330 мВт; h_{FE1} > 110...220; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
K1	HSMF3831	HP	pin	$I_B < 1 А; V_{RR} > 200 В; R_{DS} < 1.5 Ом; C_D < 0.3 пФ$	SOT23, SOD23	n.c. •A•K
K1	MMBZ5251BT	DIODS	dz	$V_{F1}(I_F = 5.6 мА) < 20.9...23.1 В; I_R < 0.1 мкА$	SOT523	A•n.c. •K
K1	YN10KT	SIL	nMOS	$V_{GS} < 60 В; I_D < 310 мА; P_D < 1000 мВт; g_{FS} < 100 мСм; R_{DS(on)} < 7.5 Ом$	SOT23, SOD23	G•S•D
K14	DTA114GE	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{FE1} > 30; f_T > 250 МГц; R_{E2} < 10 кОм$	SOT416, SC75A	B•E•C
K14	DTA114GKA	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{FE1} > 30; f_T > 250 МГц; R_{E2} < 10 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
K14	DTA114GUA	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{FE1} > 30; f_T > 250 МГц; R_{E2} < 10 кОм$	SOT323, SC70	B•E•C
K15	DTA124GKA	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{FE1} > 56; f_T > 250 МГц; R_{E2} < 22 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
K15	DTA124GUA	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{FE1} > 56; f_T > 250 МГц; R_{E2} < 22 кОм$	SOT323, SC70	B•E•C
K16	DTA144GKA	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{FE1} > 68; f_T > 250 МГц; R_{E2} < 47 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
K16	DTA144GUA	ROHM	Dnpnp	$V_{CEB} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{FE1} > 68; f_T > 250 МГц; R_{E2} < 47 кОм$	SOT323, SC70	B•E•C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
K19	DTA115GE	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE} > 82; f_T > 250 МГц; R_{\theta} = 100 К/Ом$	SOT416, SC75A	В+Е+С
K19	DTA115GKA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 82; f_T > 250 МГц; R_{\theta} = 100 К/Ом$	SOT346, SC59	В+Е+С
K19	DTA115GUA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 82; f_T > 250 МГц; R_{\theta} = 100 К/Ом$	SOT323, SC70	В+Е+С
K1E	BC847A	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 110...220; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1E	BC848A	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 110...220; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1F	BC847B	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 200...450; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1F	BC848B	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 200...450; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1G	MMSTA05	DIODS	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 100; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	В+Е+С
K1G	MMSTA06	DIODS	npn	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 100; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	В+Е+С
K1H	MMSTA05	DIODS	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 100; f_T > 100 МГц$	SOT323, SC70	В+Е+С
K1J	BC848A	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 110...220; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1K	BC848B	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 200...450; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1L	BC848C	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 420...800; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1M	BC847C	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 420...800; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1M	BC848C	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 420...800; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1N	MMB73904	VISH	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 100...300; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1O	KS43265	SAMS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 800 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 100...200; f_T > 120 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1p	BCW71	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE} > 110...220; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1P	MMB72222A	VISH	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 800 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1Q	BC846A	DIODS	npn	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE} > 110...220; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1Q	BC847A	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 110...220; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1Q	BC848A	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 110...220; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1R	BC846B	DIODS	npn	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 200...450; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1R	BC847B	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 200...450; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1R	BC848B	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 200...450; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1I	BCW71	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE} > 110...220; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K1Y	KS43265	SAMS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 800 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 160...320; f_T > 120 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K2	BCW72	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_{C0} < 100 мА; h_{FE} > 200...450; V_{CE(sat)} < 0.25 В$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K2	BCW72	CDIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE} > 200...450; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K2	BCW72	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE} > 200...450; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K2	HSMPS832	HP	pin-2	$I_C < 1 А; V_{CE0} > 200 В; R_{\theta} < 1.5 К/Ом; C_{\theta} < 0.3 нФ$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
K2	MMBZ5252BT	DIODS	dz	$V_{Z}(I_{ZT} = 5.2 мА) = 22.8...25.2 В; I_{ZT} < 0.1 мкА$	SOT523	A-n.c.-K
K24	DTC114GKA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 30; f_T > 250 МГц; R_{\theta} = 10 К/Ом$	SOT346, SC59	В+Е+С
K24	DTC114GUA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 30; f_T > 250 МГц; R_{\theta} = 10 К/Ом$	SOT323, SC70	В+Е+С
K25	DTA124GKA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 56; f_T > 250 МГц; R_{\theta} = 22 К/Ом$	SOT346, SC59	В+Е+С
K25	DTA124GUA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 56; f_T > 250 МГц; R_{\theta} = 22 К/Ом$	SOT323, SC70	В+Е+С
K25	DTC124GKA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 56; f_T > 250 МГц; R_{\theta} = 22 К/Ом$	SOT346, SC59	В+Е+С
K25	DTC124GUA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 56; f_T > 250 МГц; R_{\theta} = 22 К/Ом$	SOT323, SC70	В+Е+С
K26	DTC144GE	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 68; f_T > 250 МГц; R_{\theta} = 47 К/Ом$	SOT416, SC75A	В+Е+С
K26	DTC144GKA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 68; f_T > 250 МГц; R_{\theta} = 47 К/Ом$	SOT346, SC59	В+Е+С
K26	DTC144GUA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 68; f_T > 250 МГц; R_{\theta} = 47 К/Ом$	SOT323, SC70	В+Е+С
K29	DTC115GE	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE} > 82; f_T > 250 МГц; R_{\theta} = 100 К/Ом$	SOT416, SC75A	В+Е+С
K29	DTC115GKA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 82; f_T > 250 МГц; R_{\theta} = 100 К/Ом$	SOT346, SC59	В+Е+С
K29	DTC115GUA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 82; f_T > 250 МГц; R_{\theta} = 100 К/Ом$	SOT323, SC70	В+Е+С
K2D	MMSTA13	DIODS	dnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 300 мА; h_{FE} > 5000; f_T > 125 МГц$	SOT323, SC70	В+Е+С
K2E	MMSTA63	DIODS	dnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 5000; f_T > 125 МГц$	SOT323, SC70	В+Е+С
K2F	MMB72907A	VISH	pinp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 500 мА; P_D = 310 мВт; h_{FE} > 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K2G	MMSTA55	DIODS	pinp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 100; f_T > 50 МГц$	SOT323, SC70	В+Е+С
K2G	MMSTA56	DIODS	pinp	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 100; f_T > 50 МГц$	SOT323, SC70	В+Е+С
K2H	MMSTA55	DIODS	pinp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 100; f_T > 50 МГц$	SOT323, SC70	В+Е+С
K2p	BCW72	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE} > 200...450; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
K2I	BCW72	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE} > 200...450; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
K2T	MMBT4403	VISH	npn	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 800 мА; P_D = 200 мВт; \eta_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K2T	MMBT4401	VISH	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 800 мА; P_D = 200 мВт; \eta_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3	BCW81	CDIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; \eta_{21} = 420...800; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3	HSPM3833	HP	pin-2	$I_F < 1 А; V_{BR} > 200 В; R_{\theta} < 1.5 ОМ; C_{\phi} < 0.3 нФ$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
K31	BCW81R	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 350 мВт; \eta_{21} = 420...800; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3A	BC856A	DIODS	npn	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 125...250; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3A	BC857A	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 110...220; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3A	BC858A	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 125...250; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3A	KDV804S	KEC	bd-2	$V_A = 15 В; I_B = 50 мА; C_2 B = 42.7 нФ; C_{\phi} = 25 нФ; R_{\theta} < 0.3 ОМ$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
K3B	BC856B	DIODS	npn	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 220...475; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3B	BC857B	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 200...450; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3B	BC858B	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 220...475; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3B	DTA1D3RE	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_{C(max)} = 100 мА; P_D = 150 мВт; \eta_{21} > 20; f_T > 250 МГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
K3B	DTA1D3RKA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 30 мА; P_D = 200 мВт; \eta_{21} > 20; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 2.7/1 кОМ$	SOT346, SC58A	B-E-C
K3B	DTA1D3RUA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_{C(max)} = 100 мА; P_D = 200 мВт; \eta_{21} > 20; f_T > 250 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
K3B	KDV804S	KEC	bd-2	$V_A = 15 В; I_B = 50 мА; C_2 B = 43.7 нФ; C_{\phi} = 25 нФ; R_{\theta} < 0.3 ОМ$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
K3C	KDV804S	KEC	bd-2	$V_A = 15 В; I_B = 50 мА; C_2 B = 44.7 нФ; C_{\phi} = 25 нФ; R_{\theta} < 0.3 ОМ$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
K3D	KDV804S	KEC	bd-2	$V_A = 15 В; I_B = 50 мА; C_2 B = 45.7 нФ; C_{\phi} = 25 нФ; R_{\theta} < 0.3 ОМ$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
K3D	MMSTA13	DIODS	dnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 300 мА; \eta_{21} > 5000; f_T > 125 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
K3D	MMSTA14	DIODS	dnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 300 мА; \eta_{21} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
K3E	KDV804S	KEC	bd-2	$V_A = 15 В; I_B = 50 мА; C_2 B = 46.7 нФ; C_{\phi} = 25 нФ; R_{\theta} < 0.3 ОМ$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
K3E	MMSTA63	DIODS	dnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; \eta_{21} > 5000; f_T > 125 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
K3E	MMSTA64	DIODS	dnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; \eta_{21} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
K3G	BC857C	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; \eta_{21} = 420...800; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3G	BC858C	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 420...800; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3J	BC858A	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 125...250; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3K	BC858B	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 220...475; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3L	BC858C	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 420...800; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3N	MMBT3906	VISH	npn	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; \eta_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3p	BCW81	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 350 мВт; \eta_{21} = 420...800; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3t	BCW81	PHIL	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 350 мВт; \eta_{21} = 420...800; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3V	BC857A	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 110...220; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3V	BC858A	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 125...250; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3W	BC857B	DIODS	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 200...450; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K3W	BC858B	DIODS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 220...475; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K4	BCW71R	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45 В; I_C = 100 мА; P_D = 350 мВт; \eta_{21} = 110...220; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K4	BCW71R	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 330 мВт; \eta_{21} = 110...220; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K4	HSPM3834	HP	pin-2	$I_F < 1 А; V_{BR} > 200 В; R_{\theta} < 1.5 ОМ; C_{\phi} < 0.3 нФ$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
K4	MMBZ5254BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5.0 мА) = 25.65...28.35 В; I_{R0} < 0.1 мкА$	SOT523	A-n.c.-K
K43	BAS40	DIODS	shd	$V_A < 40 В; I_A < 200 мА; V_F(I_F = 40 мА) < 1.0 В; I_B < 0.2 мкА; C_{\phi} < 5.0 нФ; t_{RR} < 5 нс$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
K44	BAS40-04	DIODS	shd-2	$V_A < 40 В; I_A < 200 мА; V_F(I_F = 40 мА) < 1 В; I_B < 1.0 мкА; C_{\phi} < 5 нФ; t_{RR} < 5 нс$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
K45	BAS40-05	DIODS	shd-2	$V_A < 40 В; I_A < 200 мА; V_F(I_F = 40 мА) < 1.0 В; I_B < 0.2 мкА; C_{\phi} < 5.0 нФ; t_{RR} < 5 нс$	SOT23, SOD23	A1-A2-K2, K1
K46	BAS40-06	DIODS	shd-2	$V_A < 40 В; I_A < 200 мА; V_F(I_F = 40 мА) < 1.0 В; I_B < 0.2 мкА; C_{\phi} < 5.0 нФ; t_{RR} < 5 нс$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
K4B	DTC1D3RE	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_{C(max)} = 100 мА; P_D = 150 мВт; \eta_{21} > 20; f_T > 250 МГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
K4B	DTC1D3RKA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 30 мА; P_D = 200 мВт; \eta_{21} > 20; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 2.7/1 кОМ$	SOT416, SC75A	B-E-C
K4B	DTC1D3RUA	ROHM	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_{C(max)} = 100 мА; P_D = 200 мВт; \eta_{21} > 20; f_T > 250 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
K5	BCW72R	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45 В; I_C = 100 мА; P_D = 350 мВт; \eta_{21} = 200...450; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K5	BCW72R	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 330 мВт; \eta_{21} = 200...450; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
K5	MMBZ5255BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT} = 4.5 мА) = 26.6...29.4 В; I_{R0} < 0.1 мкА$	SOT523	A-n.c.-K
K51	BAV170	DIODS	di-2	$V_A < 85 В; I_A < 215 мА; V_F(I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_B < 0.005 мкА; C_{\phi} < 2.0 нФ; t_{RR} < 3000 нс$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
K52	BAV199	DIODS	di-2	$V_R < 85 \text{ В}; I_R < 160 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R1} < 0.005 \text{ мА}; C_0 > 2.0 \text{ пФ}; t_{\text{рег}} < 3000 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1•K2•K1,A2
K6	BCV71R	ZETEX	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 80 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_0 < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 110 \dots 220; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
K6	BCV71R	PHIL	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 80 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_0 < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 110 \dots 220; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	C•B•E
K7	BCV71	CDIL	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 80 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_0 < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 110 \dots 220; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
K7	BCV71	ZETEX	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 80 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_0 < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 110 \dots 220; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
K72	2N7002	DIODS	nFET	$V_{\text{СЭБ}} < 60 \text{ В}; I_D < 115 \text{ мА}; P_0 < 300 \text{ мВт}; V_{\text{GSmax}} < 1 \dots 2.5 \text{ В}; C_{\text{ISS}} < 50 \text{ пФ}$	SOT23, SOD23	G•S•D
K73	BAS70	DIODS	shd	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 70 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 15 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мА}; C_0 < 2.0 \text{ пФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A•n.c. • K
K74	BAS70-04	DIODS	shd-2	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 70 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 15 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мА}; C_0 < 2.0 \text{ пФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1•K2•K1,A2
K75	BAS70-05	DIODS	shd-2	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 70 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 15 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мА}; C_0 < 2.0 \text{ пФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
K76	BAS70-06	DIODS	shd-2	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 70 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 15 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мА}; C_0 < 2.0 \text{ пФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2
K7A	2N7002-01	DIODS	nFET	$V_{\text{СЭБ}} < 60 \text{ В}; I_D < 115 \text{ мА}; P_0 < 300 \text{ мВт}; V_{\text{GSmax}} < 1 \dots 2 \text{ В}; C_{\text{ISS}} < 50 \text{ пФ}$	SOT23, SOD23	G•S•D
K7C	BAS70	DIODS	shd	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 70 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 15 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мА}; C_0 < 2.0 \text{ пФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A•n.c. • K
K7D	BAS70-04	DIODS	shd-2	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 70 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 15 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мА}; C_0 < 2.0 \text{ пФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1•K2•K1,A2
K7E	BAS70-05	DIODS	shd-2	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 70 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 15 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мА}; C_0 < 2.0 \text{ пФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
K7E	BAS70-06	DIODS	shd-2	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 70 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 15 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мА}; C_0 < 2.0 \text{ пФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2
K7P	BCV71	PHIL	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 80 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_0 < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 110 \dots 220; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
K7L	BCV71	PHIL	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 80 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_0 < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 110 \dots 220; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
K8	BCV72	CDIL	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 80 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_0 < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 200 \dots 450; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
K8	BCV72	ZETEX	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 80 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_0 < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 200 \dots 450; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
K8p	BCV72	PHIL	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 80 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_0 < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 200 \dots 450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
K8t	BCV72	PHIL	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 80 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_0 < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 200 \dots 450; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
K9	1SS348	TOSH	shd	$V_R > 80 \text{ В}; V_{F1}(I_F = 100 \text{ мА}) < 0.7 \text{ В}; I_{R1}(V_R = 80 \text{ В}) < 5 \text{ мА}; C_0 < 100 \text{ пФ}$	SOT346, SCS59	A1•n.c. • K
K9	BCV72R	ZETEX	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 80 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_0 < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 200 \dots 450; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
K9	BCV72R	PHIL	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 80 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_0 < 330 \text{ мВт}; h_{21} > 200 \dots 450; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	C•B•E
K9l	BCF81R	PHIL	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 45 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_0 < 350 \text{ мВт}; h_{21} > 420 \dots 800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	E•B•C
K9p	BCF81	PHIL	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_0 < 250 \text{ мВт}; h_{21} > 420 \dots 800; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
KA	RN1441A	TOSH	Dnnp	$V_{\text{СЭБ}} < 50 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; P_0 < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 200 \dots 700; f_T > 30 \text{ МГц}; R_1 < 5.6 \text{ кОм}$	SOT346, SCS59	B•E•C
KA2	MMBD1448	VISH	fd	$V_R < 75 \text{ В}; I_R < 300 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 10 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R1} < 5.0 \text{ мА}; C_0 < 4 \text{ пФ}; t_{\text{рег}} < 5 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1•n.c. • K
KA3	MMBD4448	VISH	fid	$V_R < 75 \text{ В}; I_R < 500 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R1} < 5.0 \text{ мА}; C_0 < 4 \text{ пФ}; t_{\text{рег}} < 4 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A•n.c. • K
KA6	BAS16	VISH	fid	$V_R < 75 \text{ В}; I_R < 500 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мА}; C_0 < 4.0 \text{ пФ}; t_{\text{рег}} < 4 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A•n.c. • K
KA8	BAS19	DIODS	fd	$V_R < 100 \text{ В}; I_R < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мА}; C_0 < 5.0 \text{ пФ}; t_{\text{рег}} < 50 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A•n.c. • K
KA8	BAS19W	DIODS	fid	$V_R < 100 \text{ В}; I_R < 400 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мА}; C_0 < 5 \text{ пФ}; t_{\text{рег}} < 50 \text{ нс}$	SOT323, SCT70	A•n.c. • K
KB	MMBT8099LT1	ON	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 80 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_0 < 225 \text{ мВт}; h_{21} > 100 \dots 300; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
KB	RN1441B	TOSH	Dnnp	$V_{\text{СЭБ}} < 50 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; P_0 < 200 \text{ мВт}; h_{21} > 350 \dots 1200; f_T > 30 \text{ МГц}; R_1 < 5.6 \text{ кОм}$	SOT346, SCS59	B•E•C
KC	BF209P	SIEM	nnp	$V_{\text{СЭБ}} < 20 \text{ В}; I_C < 30 \text{ мА}; P_0 < 280 \text{ мВт}; h_{21} > 50 \dots 250; f_T > 5000 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
KD1	AZ23C2V7	DIODS	dz-2	$V_2 < 2.5 \dots 2.9 \text{ В}; R_{21}(I_2 = 5 \text{ мА}) < 83 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2
KD2	AZ23C3V0	DIODS	dz-2	$V_2 < 2.8 \dots 3.2 \text{ В}; R_{21}(I_2 = 5 \text{ мА}) < 95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2
KD3	AZ23C3V3	DIODS	dz-2	$V_2 < 3.1 \dots 3.5 \text{ В}; R_{21}(I_2 = 5 \text{ мА}) < 95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2
KD4	AZ23C3V6	DIODS	dz-2	$V_2 < 3.4 \dots 3.8 \text{ В}; R_{21}(I_2 = 5 \text{ мА}) < 95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2
KD5	AZ23C3V9	DIODS	dz-2	$V_2 < 3.7 \dots 4.1 \text{ В}; R_{21}(I_2 = 5 \text{ мА}) < 95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2
KD6	AZ23C4V3	DIODS	dz-2	$V_2 < 4.0 \dots 4.6 \text{ В}; R_{21}(I_2 = 5 \text{ мА}) < 95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2
KD7	AZ23C4V7	DIODS	dz-2	$V_2 < 4.4 \dots 5.0 \text{ В}; R_{21}(I_2 = 5 \text{ мА}) < 78 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2
KD8	AZ23C5V1	DIODS	dz-2	$V_2 < 4.8 \dots 5.4 \text{ В}; R_{21}(I_2 = 5 \text{ мА}) < 60 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2
KD9	AZ23C5V6	DIODS	dz-2	$V_2 < 5.2 \dots 6.0 \text{ В}; R_{21}(I_2 = 5 \text{ мА}) < 40 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2
KD9	AZ23C5V6W	DIODS	dz-2	$V_2 < 5.32 \dots 5.88 \text{ В}; R_{21}(I_2 = 5 \text{ мА}) < 40 \text{ Ом}$	SOT323, SCT70	K1•K2•A1,A2
KDA	AZ23C6V2	DIODS	dz-2	$V_2 < 5.8 \dots 6.6 \text{ В}; R_{21}(I_2 = 5 \text{ мА}) < 10 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2
KDB	AZ23C6V8	DIODS	dz-2	$V_2 < 6.4 \dots 7.2 \text{ В}; R_{21}(I_2 = 5 \text{ мА}) < 8 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2
KDB	AZ23C6V8W	DIODS	dz-2	$V_2 < 6.47 \dots 7.14 \text{ В}; R_{21}(I_2 = 5 \text{ мА}) < 8 \text{ Ом}$	SOT323, SCT70	K1•K2•A1,A2
KDC	AZ23C7V5	DIODS	dz-2	$V_2 < 7.0 \dots 7.9 \text{ В}; R_{21}(I_2 = 5 \text{ мА}) < 7 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
KDD	AZ23C8V2	DIODS	dz-2	$V_2: 7.7...8.7$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 7 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDE	AZ23C9V1	DIODS	dz-2	$V_2: 8.5...9.6$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 10 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDF	AZ23C10	DIODS	dz-2	$V_2: 9.4...10.6$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDF	AZ23C10W	DIODS	dz-2	$V_2: 9.4...10.6$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}$	SOT323, SC70	K1-K2-A1, A2
KDG	AZ23C11	DIODS	dz-2	$V_2: 10.4...11.6$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 20 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDH	AZ23C12	DIODS	dz-2	$V_2: 11.4...12.7$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 20 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDI	AZ23C13	DIODS	dz-2	$V_2: 12.4...14.1$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 25 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDJ	AZ23C15	DIODS	dz-2	$V_2: 13.8...15.6$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDK	AZ23C16	DIODS	dz-2	$V_2: 15.3...17.1$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 40 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDL	AZ23C18	DIODS	dz-2	$V_2: 16.8...19.1$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 50 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDL	AZ23C18W	DIODS	dz-2	$V_2: 16.8...19.1$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 50 \text{ Ом}$	SOT323, SC70	K1-K2-A1, A2
KDM	AZ23C20	DIODS	dz-2	$V_2: 18.8...21.2$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 50 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDN	AZ23C22	DIODS	dz-2	$V_2: 20.8...23.3$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 55 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDO	AZ23C24	DIODS	dz-2	$V_2: 22.8...25.6$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDP	AZ23C27	DIODS	dz-2	$V_2: 25.1...28.9$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDQ	AZ23C30	DIODS	dz-2	$V_2: 28...32$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDR	AZ23C33	DIODS	dz-2	$V_2: 31...35$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDS	AZ23C36	DIODS	dz-2	$V_2: 34...38$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 90 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KDT	AZ23C39	DIODS	dz-2	$V_2: 37...41$ В; $R_{f1}(I_2: 5 \text{ mA}) < 90 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KE	2SK1062	TOSH	nMOS	$V_{DS}: 60 \text{ В}; I_D: 200 \text{ mA}; P_D: 200 \text{ мВт}; R_{\theta(Son)}: 0.6 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	G-S-D
KF	2SJ168	TOSH	pMOS	$V_{DS}: 60 \text{ В}; I_D: 200 \text{ mA}; P_D: 200 \text{ мВт}; R_{\theta(Son)}: 1.3 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	G-S-D
KG	BRC123CEM	REN	Dnpn	$V_{CE}: 50 \text{ В}; I_{COUT}: 100 \text{ mA}; P_D: 150 \text{ мВт}; I_{T21} > 20; 2.2 \text{ к}/2.2 \text{ к}$	SOT323, SC70	B-E-C
KG	BRC123EMP	REN	Dnpn	$V_{CE}: 50 \text{ В}; I_{COUT}: 100 \text{ mA}; P_D: 150 \text{ мВт}; I_{T21} > 20; 2.2 \text{ к}/2.2 \text{ к}$	SOT23, SOD23	B-E-C
KH	2SK1826	TOSH	nMOS	$V_{DS}: 50 \text{ В}; I_D: 50 \text{ mA}; P_D: 200 \text{ мВт}; R_{\theta(Son)}: 20 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	G-S-D
KH	2SK1827	TOSH	nFET	$V_{DS}: 50 \text{ В}; I_D: 50 \text{ mA}; R_{\theta(Son)} < 50 \text{ Ом}; g_e > 20 \text{ мСм}; P_D: 100 \text{ мВт}$	SOT323, SC70	G-S-D
KI	2SK1828	TOSH	nMOS	$V_{DS}: 20 \text{ В}; I_D: 50 \text{ mA}; P_D: 100 \text{ мВт}; R_{\theta(Son)}: 20 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	G-S-D
KI	2SK1829	TOSH	nMOS	$V_{DS}: 20 \text{ В}; I_D: 50 \text{ mA}; R_{\theta(Son)} < 40 \text{ Ом}; g_e > 20 \text{ мСм}; P_D: 100 \text{ мВт}$	SOT323, SC70	G-S-D
KI	2SK1830	TOSH	nFET	$V_{DS}: 20 \text{ В}; I_D: 50 \text{ mA}; P_D: 200 \text{ мВт}; R_{\theta(Son)}: 20 \text{ Ом}$	SOT416, SC75A	G-S-D
KID	2SC4050D	REN	npn	$V_{CEB}: 120 \text{ В}; I_C: 100 \text{ mA}; P_D: 150 \text{ мВт}; I_{T21}: 250...500$	SOT23, SOD23	B-E-C
KIE	2SC4050E	REN	npn	$V_{CEB}: 120 \text{ В}; I_C: 100 \text{ mA}; P_D: 150 \text{ мВт}; I_{T21}: 400...800$	SOT23, SOD23	B-E-C
KJ	2SK2036	TOSH	nMOS	$V_{DS}: 20 \text{ В}; I_D: 100 \text{ mA}; P_D: 200 \text{ мВт}; R_{\theta(Son)}: 3.5 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	G-S-D
KJ	2SK2037	TOSH	nMOS	$V_{DS}: 20 \text{ В}; I_D: 100 \text{ mA}; R_{\theta(Son)} < 6 \text{ Ом}; g_e > 35 \text{ мСм}; P_D: 100 \text{ мВт}$	SOT323, SC70	G-S-D
KJA	BAV70W	DIODS	di-2	$V_R < 75 \text{ В}; I_R < 300 \text{ mA}; V_{F1}(I_R: 50 \text{ mA}) < 1.0 \text{ В}; C_D < 2 \text{ нФ}; t_{TRR} < 6 \text{ нС}$	SOT323, SC70	A1-A2-K1, K2
KJC	BAW56W	DIODS	di-2	$V_R < 75 \text{ В}; I_R < 300 \text{ mA}; V_{F1}(I_R: 150 \text{ mA}) < 1.25 \text{ В}; I_R < 2 \text{ мкА}; t_{TRR} < 4 \text{ нС}$	SOT323, SC70	K1-K2-A1, A2
KJD	BAW56	VISH	di-2	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 300 \text{ mA}; V_{F1}(I_R: 150 \text{ mA}) < 1.25 \text{ В}; I_R < 5.0 \text{ мкА}; C_D < 4.0 \text{ нФ}; t_{TRR} < 6 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KJE	BAV99	VISH	di-2	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 300 \text{ mA}; V_{F1}(I_R: 150 \text{ mA}) < 1.25 \text{ В}; I_R < 5.0 \text{ мкА}; C_D < 4.0 \text{ нФ}; t_{TRR} < 6 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
KJE	BAV99	DIODS	di-2	$V_R < 75 \text{ В}; I_R < 300 \text{ mA}; V_{F1}(I_R: 150 \text{ mA}) < 1.25 \text{ В}; I_R < 2 \text{ мкА}; t_{TRR} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
KJF	BAL99	VISH	di	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 250 \text{ mA}; V_{F1}(I_R: 50 \text{ mA}) < 1.0 \text{ В}; I_R < 2.5 \text{ мкА}; C_D < 1.5 \text{ нФ}; t_{TRR} < 6 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	n.c.-K-A
KJG	BAV99W	DIODS	di-2	$V_R < 75 \text{ В}; I_R < 300 \text{ mA}; V_{F1}(I_R: 150 \text{ mA}) < 1.25 \text{ В}; I_R < 2 \text{ мкА}; t_{TRR} < 4 \text{ нС}$	SOT323, SC70	A1-K2-K1, A2
KJG	BAV99W	DIOT	di-2	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 200 \text{ mA}; V_{F1}(I_R: 150 \text{ mA}) < 1.25 \text{ В}; I_R < 2 \text{ мкА}; t_{TRR} < 4 \text{ нС}$	SOT323, SC70	A1-K1, A2-K2
KJU	BAV70	VISH	di-2	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 300 \text{ mA}; V_{F1}(I_R: 150 \text{ mA}) < 1.25 \text{ В}; I_R < 5.0 \text{ мкА}; C_D < 4.0 \text{ нФ}; t_{TRR} < 6 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
KK	2SK2823	TOSH	nMOS	$V_{DS}: 20 \text{ В}; I_D: 100 \text{ mA}; P_D: 200 \text{ мВт}; R_{\theta(Son)}: 7 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	G-S-D
KK	2SK2824	TOSH	nMOS	$V_{DS}: 20 \text{ В}; I_D: 100 \text{ mA}; R_{\theta(Son)} < 28 \text{ Ом}; g_e > 35 \text{ мСм}; P_D: 100 \text{ мВт}$	SOT323, SC70	G-S-D
KK	2SK2825	TOSH	nFET	$V_{DS}: 20 \text{ В}; I_D: 100 \text{ mA}; P_D: 200 \text{ мВт}; R_{\theta(Son)}: 10 \text{ Ом}$	SOT416, SC75A	G-S-D
KL1	BAT54	DIOT	shd	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 300 \text{ mA}; V_{F1}(I_R: 30 \text{ mA}) < 500 \text{ мВ}; C_D < 10 \text{ пФ}; t_{TRR} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KL1	BAT54	DIODS	shd	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ mA}; V_{F1}(I_R: 30 \text{ mA}) < 500 \text{ мВ}; C_D < 10 \text{ пФ}; t_{TRR} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KL1	BAT54	VISH	shd	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ mA}; V_{F1}(I_R: 100 \text{ mA}) < 1.0 \text{ В}; I_R < 2 \text{ мкА}; C_D < 10 \text{ пФ}; t_{TRR} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KL2	BAS54A	VISH	shd-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ mA}; P_D: 200 \text{ мВт}; t_{TRR} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
KL2	BAT54A	DIOT	shd-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 300 \text{ mA}; V_{F1}(I_R: 30 \text{ mA}) < 500 \text{ мВ}; C_D < 10 \text{ пФ}; t_{TRR} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типонаимал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
KL2	BAT54A	DIODS	shd-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; V_{F(I_F=30 \text{ мА})} < 500 \text{ мВ}; C_D < 10 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2
KL2	BAT54A	VISH	shd-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; V_{F(I_F=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_{\text{R}} < 2.0 \text{ мкА}; C_D < 10 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1,A2
KL3	BAS54C	VISH	shd-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; I_{\text{рег}} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
KL3	BAT54B	VISH	shd-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; V_{F(I_F=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_{\text{R}} < 2.0 \text{ мкА}; C_D < 10 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
KL3	BAT54C	DIOT	shd-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 300 \text{ мА}; V_{F(I_F=30 \text{ мА})} < 500 \text{ мВ}; C_D < 10 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
KL3	BAT54C	DIODS	shd-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; V_{F(I_F=30 \text{ мА})} < 500 \text{ мВ}; C_D < 10 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
KL4	BAS54S	VISH	shd-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; I_{\text{рег}} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1•K2•K1,A2
KL4	BAT54S	DIOT	shd-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 300 \text{ мА}; V_{F(I_F=30 \text{ мА})} < 500 \text{ мВ}; C_D < 10 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1•K2•K1,A2
KL4	BAT54S	DIODS	shd-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; V_{F(I_F=30 \text{ мА})} < 500 \text{ мВ}; C_D < 10 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1•K2•K1,A2
KL4	BAT54S	VISH	shd-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; V_{F(I_F=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_{\text{R}} < 2.0 \text{ мкА}; C_D < 10 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 5 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1•K2•K1,A2
KM	2SK2009	TOSH	nMOS	$V_{\text{рег}}=30 \text{ В}; I_D=200 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_{\text{D(отс)}} \approx 1.2 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	G•S•D
KN	2SJ305	TOSH	pMOS	$V_{\text{рег}}=30 \text{ В}; I_D=200 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_{\text{D(отс)}} \approx 2.4 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	G•S•D
KP	2SK2033	TOSH	nMOS	$V_{\text{рег}}=20 \text{ В}; I_D=100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_{\text{D(отс)}} \approx 8 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	G•S•D
KP	2SK2034	TOSH	nMOS	$V_{\text{рег}} > 20 \text{ В}; I_D=100 \text{ мА}; R_{\text{D(отс)}} < 12 \text{ Ом}; g_{\text{p}} > 25 \text{ мСм}; P_D < 100 \text{ мВт}$	SOT323, SC70	G•S•D
KP	2SK2035	TOSH	nFET	$V_{\text{рег}}=20 \text{ В}; I_D=100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_{\text{D(отс)}} \approx 8 \text{ Ом}$	SOT416, SC75A	G•S•D
KQ	2SJ343	TOSH	pMOS	$V_{\text{рег}}=50 \text{ В}; I_D=50 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_{\text{D(отс)}} \approx 20 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	G•S•D
KQ	2SJ344	TOSH	pMOS	$V_{\text{рег}} > 50 \text{ В}; I_D=50 \text{ мА}; R_{\text{D(отс)}} < 50 \text{ Ом}; g_{\text{p}} > 15 \text{ мСм}; P_D < 100 \text{ мВт}$	SOT323, SC70	G•S•D
KS	2SJ345	TOSH	pMOS	$V_{\text{рег}}=20 \text{ В}; I_D=50 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_{\text{D(отс)}} \approx 20 \text{ Ом}$	SOT346, SC59	G•S•D
KS	2SJ346	TOSH	pMOS	$V_{\text{рег}} > 20 \text{ В}; I_D=50 \text{ мА}; R_{\text{D(отс)}} < 40 \text{ Ом}; g_{\text{p}} > 15 \text{ мСм}; P_D < 100 \text{ мВт}$	SOT323, SC70	G•S•D
KS	2SJ347	TOSH	pFET	$V_{\text{рег}}=20 \text{ В}; I_D=50 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_{\text{D(отс)}} \approx 20 \text{ Ом}$	SOT416, SC75A	G•S•D
KT2	BAS19	DIODS	fd	$V_R < 100 \text{ В}; I_R < 250 \text{ мА}; V_{F(I_F=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_{\text{R}} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 50 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
KT2	BAS19W	DIODS	fd	$V_R < 100 \text{ В}; I_R < 400 \text{ мА}; V_{F(I_F=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_{\text{R}} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 50 \text{ нС}$	SOT323, SC70	A•n.c.•K
KT2	BAS20	DIODS	fd	$V_R < 150 \text{ В}; I_R < 250 \text{ мА}; V_{F(I_F=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_{\text{R}} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 50 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
KT2	BAS20W	DIODS	fd	$V_R < 150 \text{ В}; I_R < 400 \text{ мА}; V_{F(I_F=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_{\text{R}} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 50 \text{ нС}$	SOT323, SC70	A•n.c.•K
KT3	BAS19	DIODS	fd	$V_R < 100 \text{ В}; I_R < 250 \text{ мА}; V_{F(I_F=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_{\text{R}} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 50 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
KT3	BAS19W	DIODS	fd	$V_R < 100 \text{ В}; I_R < 400 \text{ мА}; V_{F(I_F=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_{\text{R}} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 50 \text{ нС}$	SOT323, SC70	A•n.c.•K
KT3	BAS20	DIODS	fd	$V_R < 150 \text{ В}; I_R < 250 \text{ мА}; V_{F(I_F=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_{\text{R}} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 50 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
KT3	BAS20W	DIODS	fd	$V_R < 150 \text{ В}; I_R < 400 \text{ мА}; V_{F(I_F=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_{\text{R}} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 50 \text{ нС}$	SOT323, SC70	A•n.c.•K
KT3	BAS21	DIODS	di	$V_R < 200 \text{ В}; I_R < 250 \text{ мА}; V_{F(I_F=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_{\text{R}} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 50 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
KT3	BAS21	DIODS	di	$V_R < 200 \text{ В}; I_R < 400 \text{ мА}; V_{F(I_F=100 \text{ мА})} < 1.0 \text{ В}; I_{\text{R}} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 5.0 \text{ пФ}; I_{\text{рег}} < 50 \text{ нС}$	SOT323, SC70	A•n.c.•K
KV	1SV264	SANYO	pin-2	$V_R > 50 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}; V_{F(I_F=50 \text{ мА})} < 0.95 \text{ В}; I_{\text{R}} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	A1•K2•K1,A2
KV	1SV267	SANYO	pin-2	$V_R > 50 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}; V_{F(I_F=50 \text{ мА})} < 0.91 \text{ В}; I_{\text{R}} < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A1•K2•K1,A2
KV1	DZ23C2V7	VISH	dz-2	$V_2=2.5...2.9 \text{ В}; Z_{T(FI_2=5 \text{ мА})}=83 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
KV1	DZ23C2V7	DIODS	dz-2	$V_2=2.5...2.9 \text{ В}; Z_{T(FI_2=5 \text{ мА})}=83 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
KV2	DZ23C3V0	VISH	dz-2	$V_2=2.8...3.2 \text{ В}; Z_{T(FI_2=5 \text{ мА})}=95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
KV2	DZ23C3V0	DIODS	dz-2	$V_2=2.8...3.2 \text{ В}; Z_{T(FI_2=5 \text{ мА})}=95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
KV3	DZ23C3V3	VISH	dz-2	$V_2=3.1...3.5 \text{ В}; Z_{T(FI_2=5 \text{ мА})}=95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
KV3	DZ23C3V3	DIODS	dz-2	$V_2=3.1...3.5 \text{ В}; Z_{T(FI_2=5 \text{ мА})}=95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
KV4	DZ23C3V6	VISH	dz-2	$V_2=3.4...3.8 \text{ В}; Z_{T(FI_2=5 \text{ мА})}=95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
KV4	DZ23C3V6	DIODS	dz-2	$V_2=3.4...3.8 \text{ В}; Z_{T(FI_2=5 \text{ мА})}=95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
KV5	DZ23C3V9	VISH	dz-2	$V_2=3.7...4.1 \text{ В}; Z_{T(FI_2=5 \text{ мА})}=95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
KV5	DZ23C3V9	DIODS	dz-2	$V_2=3.7...4.1 \text{ В}; Z_{T(FI_2=5 \text{ мА})}=95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
KV6	DZ23C4V3	VISH	dz-2	$V_2=4.0...4.6 \text{ В}; Z_{T(FI_2=5 \text{ мА})}=95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2
KV6	DZ23C4V3	DIODS	dz-2	$V_2=4.0...4.6 \text{ В}; Z_{T(FI_2=5 \text{ мА})}=95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1,K2

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
KV7	DZ23CAV7	VISH	dz-2	V ₂ -4.4...5.0 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-78 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KV7	DZ23CAV7	DIODS	dz-2	V ₂ -4.0...4.6 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-95 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KV8	DZ23CV1	VISH	dz-2	V ₂ -4.8...5.4 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-60 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KV8	DZ23CV1	DIODS	dz-2	V ₂ -4.8...5.4 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-60 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KV9	DZ23CV6	VISH	dz-2	V ₂ -5.2...6.0 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-40 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KV9	DZ23CV6	DIODS	dz-2	V ₂ -5.2...6.0 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-40 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVA	DZ23CV2	VISH	dz-2	V ₂ -5.8...6.6 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-10 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVA	DZ23CV2	DIODS	dz-2	V ₂ -5.8...6.6 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-10 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVB	DZ23CV8	VISH	dz-2	V ₂ -6.4...7.2 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-8 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVB	DZ23CV8	DIODS	dz-2	V ₂ -6.4...7.2 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-8 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVC	DZ23CV5	VISH	dz-2	V ₂ -7.0...7.9 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-7 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVC	DZ23CV5	DIODS	dz-2	V ₂ -7.0...7.9 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-7 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVD	DZ23CV2	VISH	dz-2	V ₂ -7.7...8.7 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-7 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVD	DZ23CV2	DIODS	dz-2	V ₂ -7.7...8.7 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-7 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVE	DZ23CV1	VISH	dz-2	V ₂ -8.5...9.6 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-10 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVE	DZ23CV1	DIODS	dz-2	V ₂ -8.5...9.6 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-10 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVF	DZ23C10	VISH	dz-2	V ₂ -9.4...10.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-15 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVF	DZ23C10	DIODS	dz-2	V ₂ -9.4...10.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-15 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVG	DZ23C11	VISH	dz-2	V ₂ -10.4...11.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-20 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVG	DZ23C11	DIODS	dz-2	V ₂ -10.4...11.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-20 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVH	DZ23C12	VISH	dz-2	V ₂ -11.4...12.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-20 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVH	DZ23C12	DIODS	dz-2	V ₂ -11.4...12.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-20 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVI	DZ23C13	VISH	dz-2	V ₂ -12.4...14.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-25 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVI	DZ23C13	DIODS	dz-2	V ₂ -12.4...14.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-25 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVJ	DZ23C15	VISH	dz-2	V ₂ -13.8...15.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-30 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVJ	DZ23C15	DIODS	dz-2	V ₂ -13.8...15.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-30 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVK	DZ23C16	VISH	dz-2	V ₂ -15.3...17.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-40 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVK	DZ23C16	DIODS	dz-2	V ₂ -15.3...17.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-40 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVL	DZ23C18	VISH	dz-2	V ₂ -16.8...19.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-50 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVL	DZ23C18	DIODS	dz-2	V ₂ -16.8...19.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-50 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVM	DZ23C20	VISH	dz-2	V ₂ -18.8...21.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-50 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVM	DZ23C20	DIODS	dz-2	V ₂ -18.8...21.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-50 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVN	DZ23C22	VISH	dz-2	V ₂ -20.8...23.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-55 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVN	DZ23C22	DIODS	dz-2	V ₂ -20.8...23.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-55 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVO	DZ23C24	VISH	dz-2	V ₂ -22.8...25.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-80 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVO	DZ23C24	DIODS	dz-2	V ₂ -22.8...25.8 B; Z _{T1} (I ₂ -5 mA)-80 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVP	DZ23C27	VISH	dz-2	V ₂ -25.1...28.8 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-80 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVP	DZ23C27	DIODS	dz-2	V ₂ -25.1...28.8 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-80 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVQ	DZ23C30	VISH	dz-2	V ₂ -28...32 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-80 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVQ	DZ23C30	DIODS	dz-2	V ₂ -28...32 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-80 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVR	DZ23C33	VISH	dz-2	V ₂ -31...35 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-80 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVR	DZ23C33	DIODS	dz-2	V ₂ -31...35 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-80 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVS	DZ23C36	VISH	dz-2	V ₂ -34...38 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-90 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVS	DZ23C36	DIODS	dz-2	V ₂ -34...38 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-90 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVT	DZ23C39	VISH	dz-2	V ₂ -37...41 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-90 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVT	DZ23C39	DIODS	dz-2	V ₂ -37...41 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-90 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVU	DZ23C43	VISH	dz-2	V ₂ -40...46 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-100 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KVU	DZ23C43	DIODS	dz-2	V ₂ -40...46 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-100 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KW	DZ23C47	VISH	dz-2	V ₂ -44...50 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-100 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KW	DZ23C47	DIODS	dz-2	V ₂ -44...50 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-100 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KWW	DZ23C51	VISH	dz-2	V ₂ -48...54 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-100 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
KWW	DZ23C51	DIODS	dz-2	V ₂ -48...54 B; Z _{T1} (I ₂ -2 mA)-100 Ом	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типонаимал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
KY1	BZX84C11	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=10.4...11.6\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 20\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KY2	BZX84C12	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=11.4...12.7\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 25\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KY3	BZX84C13	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=12.4...14.1\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 30\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KY4	BZX84C15	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=13.8...15.6\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 30\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KY5	BZX84C16	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=15.3...17.1\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 40\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KY6	BZX84C18	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=16.8...19.1\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 45\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KY7	BZX84C20	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=18.8...21.2\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 55\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KY8	BZX84C22	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=20.8...23.3\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 55\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KY9	BZX84C24	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=22.8...25.6\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 70\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KYA	BZX84C27	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA})=25.1...28.9\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA}) < 80\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KYB	BZX84C30	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA})=28.0...32.0\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA}) < 80\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KYC	BZX84C33	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA})=31.0...35.0\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA}) < 80\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KYD	BZX84C36	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA})=33.0...38.0\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA}) < 90\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KYE	BZX84C39	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA})=36.0...41.0\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA}) < 130\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KYF	BZX84C43	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA})=40.0...46.0\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA}) < 150\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KYG	BZX84C47	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA})=44.0...50.0\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA}) < 170\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KYH	BZX84C51	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA})=48.0...54.0\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=2\text{ mA}) < 180\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KZ1	BZX84C4V7	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=4.4...5.0\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 80\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KZ2	BZX84C5V1	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=4.8...5.4\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 60\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KZ3	BZX84C5V6	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=5.2...6.0\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 40\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KZ4	BZX84C6V2	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=5.8...6.6\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 10\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KZ5	BZX84C6V8	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=6.4...7.2\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KZ6	BZX84C7V5	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=7.0...7.9\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KZ7	BZX84C8V2	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=7.7...8.9\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KZ8	BZX84C9V1	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=8.5...9.6\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KZ9	BZX84C10	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=9.4...10.6\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 20\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KZC	BZX84C2V7	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=2.51...2.89\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 100\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KZD	BZX84C3V0	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5.0\text{ mA})=2.8...3.2\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 100\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KZE	BZX84C3V3	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=3.1...3.5\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 95\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KZF	BZX84C3V6	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=3.4...3.8\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 95\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KZG	BZX84C3V9	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=3.7...4.1\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 90\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
KZH	BZX84C4V3	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA})=4.0...4.6\text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 90\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
L0	HSMP3860	HP	pin	$I_{\text{F}} < 1\text{ A}; V_{\text{BR}} > 50\text{ B}; R_{\text{S}}(I_{\text{F}})=3.0\text{ Ом}; C_{\text{O}}(\text{тип}) < 0.20\text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
L0	HSMP386B	HP	pin	$I_{\text{F}} < 1\text{ A}; V_{\text{BR}} > 50\text{ B}; R_{\text{S}}(I_{\text{F}})=3.0\text{ Ом}; \text{CT}(\text{тип}) < 0.20\text{ нФ}$	SOT23, SC70	A-n.c.-K
L05	ZLLS500	ZETEX	shd	$V_{\text{A}} < 40\text{ B}; I_{\text{F}} < 0.7\text{ A}; V_{\text{F}}(I_{\text{F}}=0.75\text{ A}) < 0.83\text{ B}; I_{\text{R}} < 10\text{ мкА}; C_{\text{O}} < 16\text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
L0p	BAT721S	PHIL	shd-2	$V_{\text{A}} < 40\text{ B}; I_{\text{F}} < 200\text{ mA}; V_{\text{F}}(I_{\text{F}}=100\text{ mA}) < 0.42\text{ B}; I_{\text{R}} < 15\text{ мкА}; C_{\text{O}} < 50\text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1,A2
L0t	BAT721S	PHIL	shd-2	$V_{\text{A}} < 40\text{ B}; I_{\text{F}} < 200\text{ mA}; V_{\text{F}}(I_{\text{F}}=100\text{ mA}) < 0.42\text{ B}; I_{\text{R}} < 15\text{ мкА}; C_{\text{O}} < 50\text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1,A2
L0W	BAT721S	PHIL	shd-2	$V_{\text{A}} < 40\text{ B}; I_{\text{F}} < 200\text{ mA}; V_{\text{F}}(I_{\text{F}}=100\text{ mA}) < 0.42\text{ B}; I_{\text{R}} < 15\text{ мкА}; C_{\text{O}} < 50\text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1,A2
L1	BSS865	ZETEX	pinp	$V_{\text{CES}}=12\text{ B}; I_{\text{C}}=100\text{ mA}; P_{\text{D}}=330\text{ мВт}; h_{21}=40...150; f_{\text{T}} > 400\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
L10	ZLLS1000	ZETEX	shd	$V_{\text{A}} < 40\text{ B}; I_{\text{F}} < 1.16\text{ A}; I_{\text{R}} < 20\text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
L14	DTB114GK	ROHM	Dnpn	$V_{\text{CES}}=50\text{ B}; I_{\text{C}}=500\text{ mA}; P_{\text{D}}=200\text{ мВт}; h_{21}=56; f_{\text{T}} > 200\text{ МГц}; R_{\text{B}} > 10\text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
L14	DTD114GK	ROHM	Dnpn	$V_{\text{CES}}=50\text{ B}; I_{\text{C}}=500\text{ mA}; P_{\text{D}}=200\text{ мВт}; h_{21}=56; f_{\text{T}} > 200\text{ МГц}; R_{\text{B}} > 10\text{ кОм}$	SOT346, SC59	B-E-C
L2	BSS699	ZETEX	pinp	$V_{\text{CES}}=40\text{ B}; I_{\text{C}}=100\text{ mA}; P_{\text{D}}=330\text{ мВт}; h_{21}=50...150; f_{\text{T}} > 200\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
L2	HSMP3862	HP	pin-2	$I_{\text{F}} < 1\text{ A}; V_{\text{BR}} > 50\text{ B}; R_{\text{S}}(I_{\text{F}})=3.0\text{ Ом}; C_{\text{O}}(\text{тип}) < 0.20\text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1,A2
L2	HSMP386C	HP	pin-2	$I_{\text{F}} < 1\text{ A}; V_{\text{BR}} > 50\text{ B}; R_{\text{S}}(I_{\text{F}})=3.0\text{ Ом}; \text{CT}(\text{тип}) < 0.20\text{ нФ}$	SOT23, SC70	A1-K2-K1,A2
L2	KC4075	KEC	npn	$V_{\text{CES}}=60\text{ B}; I_{\text{C}}=150\text{ mA}; P_{\text{D}}=100\text{ мВт}; h_{21}=70...140; f_{\text{T}} > 80\text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
L20	BAS29	PHIL	di	$V_{\text{A}} < 90\text{ B}; I_{\text{F}} < 250\text{ mA}; V_{\text{F}}(I_{\text{F}}=200\text{ mA}) < 1.0\text{ B}; C_{\text{O}} < 35\text{ нФ}; t_{\text{BR}} < 50$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
L20	CMPD1001	CSI	dh	$I_{\text{F}} < 250\text{ mA}; V_{\text{A}}=90\text{ B}; V_{\text{F}}(I_{\text{F}}=10\text{ mA}) < 0.75\text{ B}; I_{\text{R}} < 100\text{ нА}; t_{\text{BR}} < 50\text{ нс}; C_{\text{T}} < 35\text{ пФ}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
L20	KSK211	SAMS	nFET	$V_{\text{DS}}=18\text{ B}; P_{\text{D}}=200\text{ мВт}; I_{\text{DSS}} > 1\text{ mA}; g_{\text{m}} > 9\text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-G-S
L21	BAS31	PHIL	dh-2	$V_{\text{A}} < 90\text{ B}; I_{\text{F}} < 250\text{ mA}; V_{\text{F}}(I_{\text{F}}=200\text{ mA}) < 1.0\text{ B}; C_{\text{O}} < 35\text{ нФ}; t_{\text{BR}} < 50\text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1,A2
L21	CMPD1001S	CSI	dh-2	$I_{\text{F}} < 250\text{ mA}; V_{\text{A}}=90\text{ B}; V_{\text{F}}(I_{\text{F}}=10\text{ mA}) < 0.75\text{ B}; I_{\text{R}} < 100\text{ нА}; t_{\text{BR}} < 50\text{ нс}; C_{\text{T}} < 35\text{ пФ}$	SOT23, SOD23	A2-K1-K2,A1
L22	BAS35	PHIL	dh-2	$V_{\text{A}} < 90\text{ B}; I_{\text{F}} < 250\text{ mA}; V_{\text{F}}(I_{\text{F}}=200\text{ mA}) < 1.0\text{ B}; C_{\text{O}} < 35\text{ нФ}; t_{\text{BR}} < 50\text{ нс}$	SOT23, SOD23	K1-K2-K1,A2



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
L4W	BAT54	PHIL	shd	$V_B < 30 В; I_C < 200 мА; V_{F(I_F=30 мА)} < 500 мВ; C_0 < 10 пФ; t_{RR} < 5 нс$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
L4Z	BAT54	ZETEX	shd	$V_B < 30 В; I_C < 200 мА; V_{F(I_F=100 мА)} < 1.0 В; I_B < 4.0 мкА; C_0 < 10 пФ; t_{RR} < 5 нс$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
L5	BSS65R	ZETEX	pinp	$V_{CBO} < 12 В; I_C < 100 мА; P_D < 330 мВт; h_{21} < 40...150; f_T > 400 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
L5	KST1623L5	SAMS	pinp	$V_{CBO} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 350 мВт; h_{21} < 135...270; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
L5	MMBC1623L5	MOT	pinp	$V_{CBO} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 300 мВт; h_{21} < 1350...270$	SOT23, SOD23	B•E•C
L52	BAS678	PHIL	fd	$V_B < 80 В; I_C < 250 мА; V_{F(I_F=200 мА)} < 1.0 В; C_0 < 2 нФ; t_{RR} < 6 нс$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
L5p	BAS55	PHIL	fd	$V_B < 60 В; I_C < 250 мА; V_{F(I_F=200 мА)} < 1.0 В; C_0 < 2.5 нФ; t_{RR} < 6 нс$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
L6	BAR17	INF	pin	$V_B < 100 В; I_C < 140 мА; V_{F(I_F=100 мА)} < 1.0 В; I_B < 0.05 мкА; C_0 < 0.37 нФ$	SOT23, SOD23	A•n.c.~K
L6	BSS69R	ZETEX	pinp	$V_{CBO} < 40 В; I_C < 100 мА; P_D < 330 мВт; h_{21} < 50...150; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
L6	KST1623L6	SAMS	pinp	$V_{CBO} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 350 мВт; h_{21} < 200...400; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
L6	KTC4075	KEC	pinp	$V_{CBO} < 60 В; I_C < 150 мА; P_D < 100 мВт; h_{21} < 200...400; f_T > 80 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
L6	MMBC1623L6	MOT	pinp	$V_{CBO} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 300 мВт; h_{21} < 200...400$	SOT23, SOD23	B•E•C
L7	BAR141	INF	pin-2	$V_B < 100 В; I_C < 140 мА; V_{F(I_F=100 мА)} < 1.05 В; I_B < 0.1 мкА; C_0 < 0.2 пФ$	SOT23, SOD23	A1•K2-K1, A2
L7	BAT17	GS	shd	$V_B < 4 В; I_C < 30 мА; V_{F(I_F=1 мА)} < 450 мВ; C_0 < 1 пФ$	SOT23, SOD23	A1•n.c.~K
L7	BAT17DS	GS	shd-2	$V_B < 4 В; I_C < 30 мА; V_{F(I_F=1 мА)} < 450 мВ; C_0 < 1 пФ$	SOT23, SOD23	A1•K2-K1, A2
L7	BSS70R	ZETEX	pinp	$V_{CBO} < 40 В; I_C < 100 мА; P_D < 330 мВт; h_{21} < 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
L7	KST1623L7	SAMS	pinp	$V_{CBO} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 350 мВт; h_{21} < 300...600; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
L7	MMBC1623L7	MOT	pinp	$V_{CBO} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 300 мВт; h_{21} < 300...600$	SOT23, SOD23	B•E•C
L7	FMMTL717	ZETEX	pinp	$V_{CBO} < 12 В; I_C < 1250 мА; P_D < 500 мВт; h_{21} > 50; f_T > 205 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
L78	FMMTL718	ZETEX	pinp	$V_{CBO} < 20 В; I_C < 1000 мА; P_D < 500 мВт; h_{21} > 50; f_T > 265 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
L7p	BAT721	PHIL	shd	$V_B < 40 В; I_C < 200 мА; V_{F(I_F=100 мА)} < 0.42 В; I_B < 15 мкА; C_0 < 50 нФ$	SOT23, SOD23	A•n.c.~K
L7i	BAT721	PHIL	shd	$V_B < 40 В; I_C < 200 мА; V_{F(I_F=100 мА)} < 0.42 В; I_B < 15 мкА; C_0 < 50 нФ$	SOT23, SOD23	A•n.c.~K
L7W	BAT721	PHIL	shd	$V_B < 40 В; I_C < 200 мА; V_{F(I_F=100 мА)} < 0.42 В; I_B < 15 мкА; C_0 < 50 нФ$	SOT23, SOD23	A•n.c.~K
L8	BAR151	INF	pin-2	$V_B < 100 В; I_C < 140 мА; V_{F(I_F=100 мА)} < 1.05 В; I_B < 0.1 мкА; C_0 < 0.2 пФ$	SOT23, SOD23	A1•A2-K1, A2
L8	KTC4075	KEC	pinp	$V_{CBO} < 60 В; I_C < 150 мА; P_D < 100 мВт; h_{21} < 350...700; f_T > 80 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
L8p	BAT721A	PHIL	shd-2	$V_B < 40 В; I_C < 200 мА; V_{F(I_F=100 мА)} < 0.42 В; I_B < 15 мкА; C_0 < 50 нФ$	SOT23, SOD23	K1•K2-A1, A2
L8t	BAT721A	PHIL	shd-2	$V_B < 40 В; I_C < 200 мА; V_{F(I_F=100 мА)} < 0.42 В; I_B < 15 мкА; C_0 < 50 нФ$	SOT23, SOD23	K1•K2-A1, A2
L8W	BAT721A	PHIL	shd-2	$V_B < 40 В; I_C < 200 мА; V_{F(I_F=100 мА)} < 0.42 В; I_B < 15 мкА; C_0 < 50 нФ$	SOT23, SOD23	K1•K2-A1, A2
L9	1SS349	TOSH	shd	$V_B > 20 В; V_{F(I_F=1 А)} < 0.55 В; I_B(I_B=20 В) < 50 мкА; C_T < 250 пФ$	SOT346, SC59	A•n.c.~K
L9	BAR161	INF	pin-2	$V_B < 100 В; I_C < 140 мА; V_{F(I_F=100 мА)} < 1.05 В; I_B < 0.1 мкА; C_0 < 0.2 пФ$	SOT23, SOD23	K1•K2-A1, A2
L9p	BAT721C	PHIL	shd-2	$V_B < 40 В; I_C < 200 мА; V_{F(I_F=100 мА)} < 0.42 В; I_B < 15 мкА; C_0 < 50 нФ$	SOT23, SOD23	A1•A2-K1, K2
L9t	BAT721C	PHIL	shd-2	$V_B < 40 В; I_C < 200 мА; V_{F(I_F=100 мА)} < 0.42 В; I_B < 15 мкА; C_0 < 50 нФ$	SOT23, SOD23	A1•A2-K1, K2
L9W	BAT721C	PHIL	shd-2	$V_B < 40 В; I_C < 200 мА; V_{F(I_F=100 мА)} < 0.42 В; I_B < 15 мкА; C_0 < 50 нФ$	SOT23, SOD23	A1•A2-K1, K2
LA	BF550	SIEM	pinp	$V_{CBO} < 40 В; I_C < 25 мА; P_D < 280 мВт; h_{21} < 50...250; f_T > 350 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
LA	RN1442A	TOSH	Dnnpn	$V_{CBO} < 50 В; I_C < 300 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} < 200...700; f_T > 30 МГц; R_1 < 10 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
LAp	BF550	PHIL	pinp	$V_{CBO} < 40 В; I_C < 25 мА; P_D < 250 мВт; h_{21} > 50; f_T > 325 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
LB	2SC2462B	REN	pinp	$V_{CBO} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} < 100...200$	SOT23, SOD23	B•E•C
LB	2SC5850B	REN	pinp	$V_{CBO} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} < 100...200$	SOT323, SC70	B•E•C
LB	RN1442B	TOSH	Dnnpn	$V_{CBO} < 50 В; I_C < 300 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} < 350...1200; f_T > 30 МГц; R_1 < 10 кОм$	SOT346, SC59	B•E•C
LB	SS527	VISH	nMOS	$V_{DS} < 20 В; I_D < 30 мА; P_D < 200 мВт; g_{fs} < 16 мСм$	SOT23, SOD23	G•D•S
LBL	KTC4075	KEC	pinp	$V_{CBO} < 60 В; I_C < 150 мА; P_D < 100 мВт; h_{21} < 350...700; f_T > 80 МГц$	SOT323, SC70	B•E•C
LBs	BF999	SIEM	nMOS	$V_{DS} < 20 В; I_D < 30 мА; P_D < 200 мВт; NF < 1.0 дБ; f_{TSS} < 5...18 мА; g_{fs} < 18 мСм$	SOT23, SOD23	G•D•S
LC	2SC2462C	REN	pinp	$V_{CBO} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} < 160...320$	SOT23, SOD23	B•E•C
LC	2SC5850C	REN	pinp	$V_{CBO} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} < 160...320$	SOT323, SC70	B•E•C
LD	2SC2462D	REN	pinp	$V_{CBO} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} < 250...500$	SOT23, SOD23	B•E•C
LD	2SC5850D	REN	pinp	$V_{CBO} < 50 В; I_C < 100 мА; P_D < 150 мВт; h_{21} < 250...500$	SOT323, SC70	B•E•C
LD	BF543	TELEF	nMOS	$V_{DS} < 20 В; I_D < 30 мА; P_D < 200 мВт; g_{fs} < 70 мСм; P_{ROSS} < 10 Ом$	SOT23, SOD23	G•D•S
LD3	BAT54S	ZOWIE	shd-2	$V_B < 30 В; V_{F(I_F=30 мА)} < 500 мВ; C_0 < 10 пФ; t_{RR} < 5 нс$	SOT23, SOD23	A1•A2-K2, K1, A2
LDs	BF543	SIEM	nMOS	$V_{DS} < 20 В; I_D < 30 мА; P_D < 200 мВт; NF < 1.0 дБ; g_{fs} < 12 мСм$	SOT23, SOD23	G•D•S
LE	2SC2412KLINE	ROHM	pinp	$V_{CBO} < 50 В; I_C < 150 мА; P_D < 200 мВт; h_{21} < 390...820; f_T > 180 МГц$	SOT346, SC59	B•E•C
LEp	BF660	PHIL	pinp	$V_{CBO} < 30 В; I_C < 25 мА; P_D < 280 мВт; h_{21} < 30; f_T > 650 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C
LEs	BF660	SIEM	pinp	$V_{CBO} < 40 В; I_C < 25 мА; P_D < 280 мВт; h_{21} > 30; f_T > 700 МГц$	SOT23, SOD23	B•E•C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
LEs	BF660W	SIEM	pnp	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 25 \text{ mA}; P_D = 280 \text{ мВт}; h_{FE1} > 30; f_T > 700 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
LG	2SC2712GR	TOSH	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 200; \dots; 400; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
LG	2SC4116	TOSH	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; h_{FE1} > 200; \dots; 400; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
LGR	KTC4075	KEC	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; h_{FE1} > 200; \dots; 400; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
LGS	BF775A	SIEM	npn	$V_{CE0} = 25 \text{ В}; I_C = 30 \text{ mA}; P_D = 280 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; \dots; 250; f_T > 5800 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
LH	BF569	TELEF	pnp	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 30 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 25; \dots; 90; f_T > 950 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
LHp	BF569	PHIL	npn	$V_{CE0} = 35 \text{ В}; I_C = 30 \text{ mA}; P_D = 280 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; f_T > 900 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
LHs	BF569	SIEM	pnp	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 30 \text{ mA}; P_D = 280 \text{ мВт}; h_{FE1} > 20; f_T > 950 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
LHs	BF569W	SIEM	pnp	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 30 \text{ mA}; P_D = 280 \text{ мВт}; h_{FE1} > 20; f_T > 950 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
LK	BF799	SIEM	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 35 \text{ mA}; P_D = 280 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; \dots; 250; f_T > 1100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
LKs	BF799W	SIEM	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 35 \text{ mA}; P_D = 280 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; \dots; 250; f_T > 1100 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	B-E-C
LL	2SC2712BL	TOSH	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 350; \dots; 700; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
LL	2SC4116	TOSH	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; h_{FE1} > 350; \dots; 700; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
LM	BF569R	TELEF	pnp	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 30 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 25; \dots; 90; f_T > 950 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
LO	2SC2712O	TOSH	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 70; \dots; 140; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
LO	2SC4116	TOSH	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; h_{FE1} > 70; \dots; 140; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
LO	KTC4075	KEC	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; h_{FE1} > 70; \dots; 140; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
LOs	BF775	SIEM	npn	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; I_C = 30 \text{ mA}; P_D = 280 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; \dots; 250; f_T > 4500 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
LOs	BF775W	SIEM	npn	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; I_C = 30 \text{ mA}; P_D = 280 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; \dots; 200; f_T > 5000 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
LR	2SC2412KLN	ROHM	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 180; \dots; 390; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
LRs	BF517	SIEM	npn	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; I_C = 25 \text{ mA}; P_D = 280 \text{ мВт}; h_{FE1} > 25; \dots; 250; f_T > 2000 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
LS	2SC2412KLS	ROHM	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 270; \dots; 560; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
LSs	BF770A	SIEM	npn	$V_{CE0} = 15 \text{ В}; I_C = 50 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 5500 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
LY	2SC2712Y	TOSH	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 120; \dots; 240; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
LY	2SC4116	TOSH	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; h_{FE1} > 120; \dots; 240; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
LY	KTC4075	KEC	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 150 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; h_{FE1} > 120; \dots; 240; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
M1	MMB2526BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT} = 4.2 \text{ mA}) = 28.5 \dots 31.5 \text{ В}; I_R < 0.1 \text{ мкА}$	SOT523	A-n.c.-K
M16	PMBF4416A	PHIL	nFET	$V_{DS} = 35 \text{ В}; I_{DSS} = 15 \text{ mA}; P_D = 250 \text{ мВт}; g_{fs} < 7.5 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	S-D-G
M1B	MMBT222ALT1	ON	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 600 \text{ mA}; P_D = 225 \text{ мВт}; h_{FE1} > 30$	SOT23, SOD23	B-E-C
M1E	MMBT443LT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 200 \text{ В}; I_C = 500 \text{ mA}; P_D = 225 \text{ мВт}; h_{FE1} > 25; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
M1J	MMBT2369LT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 200 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; \dots; 120$	SOT23, SOD23	B-E-C
M1p	BF930	PHIL	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; I_{DSS} = 10 \text{ mA}; P_D = 250 \text{ мВт}; g_{fs} < 4 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
M1T	ADM1811-10AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 4.35 \text{ В}; V_{D0} = 1 \dots 5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} , RST, GND
M1T	ADM1811-10ART	AD	mrc	$V_{TR} = 4.35 \text{ В}; V_{D0} = 1 \dots 5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST, V_{CC} , GND
M1V	ADM1811-5AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 4.62 \text{ В}; V_{D0} = 1 \dots 5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} , RST, GND
M1V	ADM1811-SART	AD	mrc	$V_{TR} = 4.62 \text{ В}; V_{D0} = 1 \dots 5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST, V_{CC} , GND
M2	MMB2525BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT} = 3.8 \text{ mA}) = 31.35 \dots 34.65 \text{ В}; I_R < 0.1 \text{ мкА}$	SOT523	A-n.c.-K
M2C	MMBT40LT1	MOT	pnp	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; \dots; 400; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
M2p	BF931	PHIL	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; I_{DSS} = 5 \text{ mA}; P_D = 250 \text{ мВт}; g_{fs} < 4.5 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
M3	KDV173	KEC	pin-2	$V_F = 50 \text{ В}; I_R = 0.1 \text{ мкА}; C_T = 0.25 \text{ пФ}; R_F < 7.0 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
M3	KST812M3	SAMS	pnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{FE1} > 60; \dots; 120$	SOT23, SOD23	B-E-C
M3	MMBA812M3	SAMS	pnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{FE1} > 60; \dots; 120$	SOT23, SOD23	B-E-C
M3	MMBA812M3	MOT	pnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{FE1} > 60; \dots; 120$	SOT23, SOD23	B-E-C
M3	MMB2526BT	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT} = 3.4 \text{ mA}) = 34.2 \dots 37.8 \text{ В}; I_R < 0.1 \text{ мкА}$	SOT523	A-n.c.-K
M3A	MMBT424LT1	MOT	pnp	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 50 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{FE1} > 30; f_T > 400 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
M3B	MMBT918LT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 50 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{FE1} > 20; f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
M3J	MMBT469LT1	MOT	pnp	$V_{CE0} = 15 \text{ В}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{FE1} > 30; \dots; 300; f_T > 2000 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
M3p	BF146	PHIL	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; I_{DSS} = 1.5 \text{ mA}; P_D = 250 \text{ мВт}; g_{fs} > 0.5 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
M3T	ADM1813-10AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 4.35 \text{ В}; V_{D0} = 1 \dots 5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} , RST, GND
M3T	ADM1813-10ART	AD	mrc	$V_{TR} = 4.35 \text{ В}; V_{D0} = 1 \dots 5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST, V_{CC} , GND
M3V	ADM1813-5AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 4.62 \text{ В}; V_{D0} = 1 \dots 5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} , RST, GND
M3V	ADM1813-SART	AD	mrc	$V_{TR} = 4.62 \text{ В}; V_{D0} = 1 \dots 5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST, V_{CC} , GND



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TSM VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
M4	BSR56	FAIR	nFET	$V_{DS} = 40 \text{ В}; I_D = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; R_{\theta DS(on)} < 25 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D•S•G
M4	KST812M4	SAMS	pnп	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 90...180$	SOT23, SOD23	B•E•C
M4	MMBA812M4	MOT	pnп	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 90...180$	SOT23, SOD23	B•E•C
M4	MMBZ5259BT	DIODS	dz	$V_{F(I_{F1} = 3.2 \text{ мА})} = 37.05...41.0 \text{ В}; I_{F1} < 0.1 \text{ мА}$	SOT523	A•n.c.•K
M4A	MMBV109LT1	MOT	var	$V_{A1} = 30 \text{ В}; I_F = 200 \text{ мА}; C_{J3} = 26...32 \text{ пФ}; C_{2B}/C_{25B} = 5.0...6.5$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
M4B	MMBV432LT1	ON	var-2	$V_{A1} = 14 \text{ В}; I_F = 200 \text{ мА}; C_{2B} = 43...48.1 \text{ пФ}; C_{2B}/C_{25B} = 1.5...2$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
M4C	MMBV3102LT1	ON	var	$V_{A1} > 30 \text{ В}; I_F = 200 \text{ мА}; C_{2B} = 20...25 \text{ пФ}; C_{2B}/C_{25B} = 4.5...4.8$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
M4E	MMBV105GLT1	ON	var	$V_{A1} > 30 \text{ В}; I_F = 200 \text{ мА}; C_{2B}/C_{25B} = 4.0...6.5$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
M4F	ADM1815-10AKSZ	AD	mrc	$V_{FR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M4F	ADM1815-10ARTZ	AD	mrc	$V_{FR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M4F	MMBD353LT1	MOT	shd-2	$V_{A2} > 7 \text{ В}; V_{F1}(I_F = 10 \text{ мА}) < 0.6 \text{ В}; C_T < 1 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K1•A2•A1, K2
M4G	MMBV2101LT1	MOT	var	$V_{A1} > 30 \text{ В}; I_F = 200 \text{ мА}; C_{J3} = 6.1...7.5 \text{ пФ}; C_{2B}/C_{25B} = 2.5...3.2$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
M4P	BSR56	PHIL	nFET	$V_{DS} = 40 \text{ В}; I_D = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; R_{\theta DS(on)} < 25 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D•S•G
M4T	ADM1818-5AKSZ	AD	mrc	$V_{FR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M4T	ADM1818-5ARTZ	AD	mrc	$V_{FR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M4Y	ADM1810-5AKSZ	AD	mrc	$V_{FR} = 4.62 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M4Y	ADM1810-5ARTZ	AD	mrc	$V_{FR} = 4.62 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M4Z	ADM1810-10AKSZ	AD	mrc	$V_{FR} = 4.35 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M4Z	ADM1810-10ARTZ	AD	mrc	$V_{FR} = 4.35 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M5	KST812M5	SAMS	pnп	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 135...270$	SOT23, SOD23	B•E•C
M5	MMBA812M5	SAMS	pnп	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 135...270$	SOT23, SOD23	B•E•C
M5	MMBA812M5	MOT	pnп	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 135...270$	SOT23, SOD23	B•E•C
M5	MMBD352WT1	IMOT	shd-2	$V_{A2} > 7 \text{ В}; V_{F1}(I_F = 10 \text{ мА}) < 0.6 \text{ В}; C_T < 1 \text{ нФ}$	SOT323, SC70	A1•K2•A2, K1
M54	ADM1816-10AKSZ	AD	mrc	$V_{FR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M54	ADM1816-10ARTZ	AD	mrc	$V_{FR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M59	ADM1818-20AKSZ	AD	mrc	$V_{FR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M59	ADM1818-20ARTZ	AD	mrc	$V_{FR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M5A	ADM1815-20AKS	AD	mrc	$V_{FR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M5A	ADM1815-20ART	AD	mrc	$V_{FR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M5B	ADM1815-R22AKS	AD	mrc	$V_{FR} = 2.18 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M5B	ADM1815-R22ART	AD	mrc	$V_{FR} = 2.18 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M5C	ADM1815-R23AKS	AD	mrc	$V_{FR} = 2.31 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M5C	ADM1815-R23ART	AD	mrc	$V_{FR} = 2.31 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M5E	MMBD7000LT1	MOT	di-2	$V_{A2} > 100 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; C_D < 1.5 \text{ пФ}; t_{\text{trr}} < 4 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1•K2•K1, A2
M5E	ADM1815-10AKS	AD	mrc	$V_{FR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M5E	ADM1815-10ART	AD	mrc	$V_{FR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M5G	MMBD352LT1	MOT	shd-2	$V_{A2} > 7 \text{ В}; V_{F1}(I_F = 10 \text{ мА}) < 0.6 \text{ В}; C_T < 1 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1•K2•A2, K1
M5K	ADM1815-5AKS	AD	mrc	$V_{FR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M5K	ADM1815-5ART	AD	mrc	$V_{FR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M5P	BSR57	PHIL	nFET	$V_{DS} = 40 \text{ В}; I_D = 20 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; R_{\theta DS(on)} < 40 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D•S•G
M6	BSS56	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{21} = 50...150; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
M6	KST812M6	SAMS	pnп	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 200...400$	SOT23, SOD23	B•E•C
M6	MMBA812M6	SAMS	pnп	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} = 200...400$	SOT23, SOD23	B•E•C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
M6	MMB4812M6	MOT	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; \eta_{21} = 200...400$	SOT23, SOD23	B-E-C
M68	PMBFJ210	PHIL	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; I_{DSS} = 2...15 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; g_{fs} = 4...12 \text{ мСМ}$	SOT23, SOD23	S-D-G
M69	PMBFJ211	PHIL	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; I_{DSS} = 7...20 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; g_{fs} = 6...12 \text{ мСМ}$	SOT23, SOD23	S-D-G
M6A	ADM1816-20AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M6A	ADM1816-20ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	V_{CC} -RST-GND
M6B	ADM1816-R22AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 2.18 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M6B	ADM1816-R22ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2.18 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	V_{CC} -RST-GND
M6C	ADM1816-R23AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 2.31 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M6C	ADM1816-R23ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2.31 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M6E	ADM1816-10AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M6E	ADM1816-10ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M6H	ADM1816-20AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M6H	ADM1816-20ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M6H	MMBD354LT1	MOT	shd-2	$V_{CE} > 7 \text{ В}; V_{CE}(I_C = 10 \text{ мА}) < 0.6 \text{ В}; C_T < 1 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
M6K	ADM1816-5AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M6K	ADM1816-5ART	AD	mrc	$V_{TR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M6P	BSR58	PHIL	nFET	$V_{DS} = 40 \text{ В}; I_D = 8 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; P_{D(SIM)} < 60 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
M6X	ADM1813-5AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 4.62 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M6X	ADM1813-SARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 4.62 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M6Y	ADM1813-10AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 4.35 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M6Y	ADM1813-10ARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 4.35 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M6Z	ADM1811-5AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 4.62 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M6Z	ADM1811-SARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 4.62 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M7	BSS67	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; \eta_{21} = 100...300; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
M7	KST812M7	SAMS	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; \eta_{21} = 300...600$	SOT23, SOD23	B-E-C
M7	MMBA812M7	SAMS	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; \eta_{21} = 300...600$	SOT23, SOD23	B-E-C
M7	MMBA812M7	MOT	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; \eta_{21} = 300...600$	SOT23, SOD23	B-E-C
M70	ADM1811-10AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 4.35 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M70	ADM1811-10ARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 4.35 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M70	PMBFJ212	PHIL	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; I_{DSS} = 15...40 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; g_{fs} = 7...12 \text{ мСМ}$	SOT23, SOD23	S-D-G
M71	ADM1812-10AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 4.35 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M71	ADM1812-10ARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 4.35 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M72	ADM1812-5AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 4.62 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M72	ADM1812-SARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 4.62 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M73	ADM1815-5AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M73	ADM1815-SARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M74	ADM1815-R22AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.18 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M74	ADM1815-R22ARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.18 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
M75	ADM1815-R23AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.31 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
M75	ADM1815-R23ARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.31 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TSM VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
M76	ADM1815-20AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M76	ADM1815-20ARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M77	ADM1816-5AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M77	ADM1816-5ARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M78	ADM1816-R22AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.18 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M78	ADM1816-R22ARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.18 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M79	ADM1816-R23AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.31 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M79	ADM1816-R23ARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.31 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M7A	ADM1817-20AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M7A	ADM1817-20ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M7B	ADM1817-R22AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 2.18 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M7B	ADM1817-R22ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2.18 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M7C	ADM1817-R23AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 2.31 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M7C	ADM1817-R23ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2.31 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M7E	ADM1817-10AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M7E	ADM1817-10ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M7F	ADM1817-5AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M7F	ADM1817-5ARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M7G	ADM1817-10AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M7G	ADM1817-10ARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M7H	ADM1817-20AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M7H	ADM1817-20ARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M7J	ADM1817-R22AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.18 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M7J	ADM1817-R22ARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.18 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M7K	ADM1817-5AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M7K	ADM1817-5ART	AD	mrc	$V_{TR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M7L	ADM1817-R23AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.31 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M7L	ADM1817-R23ARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.31 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M7N	ADM1818-R23AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 2.31 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M7N	ADM1818-R23AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.31 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M7P	ADM1818-10AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M7P	ADM1818-10ARTZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$
M8	BSH103	PHIL	mMOS	$V_{DS} = 30 \text{ В}; I_D = 850 \text{ мА}; P_D = 500 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 0.5 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
M8	BSS669	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; \eta_{21} = 50...150; I_E > 250 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	B-E-C
M8A	ADM1818-20AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC} - RST - GND$
M8A	ADM1818-20ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2.55 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$RST - V_{CC} - GND$

SOT490 **TESM** **VMT3**
MFFPAK **TSFP-3** **VMD3**



SOT416 **SOT323** **SOT23-3**
SOT523 **SOT346** **SOD23-3**



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
M8B	ADM1818-R22AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 2.18 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC}; \overline{\text{RST}}; \text{GND}$
M8C	ADM1818-R22AKSZ	AD	mrc	$V_{TR} = 2.18 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC}; \overline{\text{RST}}; \text{GND}$
M8C	ADM1818-R22ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2.18 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$\overline{\text{RST}}; V_{CC}; \text{GND}$
M8C	ADM1818-R23ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2.31 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC}; \overline{\text{RST}}; \text{GND}$
M8E	ADM1818-10AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC}; \overline{\text{RST}}; \text{GND}$
M8E	ADM1818-10ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2.88 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$\overline{\text{RST}}; V_{CC}; \text{GND}$
M8E	ADM1818-5AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC}; \overline{\text{RST}}; \text{GND}$
M8K	ADM1818-SART	AD	mrc	$V_{TR} = 3.06 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$\overline{\text{RST}}; V_{CC}; \text{GND}$
M8p	BSN20	PHIL	nMOS	$V_{DS} = 50 \text{ В}; I_D = 110 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	G-S-D
M9	BSS67R	ZETEX	npn	$V_{CE} = 60 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
MA	FMMTA06R	ZETEX	npn	$V_{CE} = 80 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
MA	M1MA151AT	MOT	di	$V_R < 40 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOT346, SC59	K-n.c.-A
MA6	MMBD2838LT1	MOT	di-2	$V_R < 50 \text{ В}; I_R < 150 \text{ мА}; V_{FI}(I_R = 50 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_0 < 4 \text{ пФ}; t_{RR} < 4 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
MB	2SA1052B	REN	npn	$V_{CE} = 30 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...200$	SOT23, SOD23	B-E-C
MB	FMMTA56R	ZETEX	npn	$V_{CE} = 80 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
MB	M1MA152AT	MOT	di	$V_R < 80 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOT346, SC59	K-n.c.-A
MC	2SA1052C	REN	npn	$V_{CE} = 30 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} = 160...320$	SOT23, SOD23	B-E-C
MC	2SA2080C	REN	npn	$V_{CE} = 30 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} = 160...320$	SOT23, SC70	B-E-C
MC	ZVN3306F	ZETEX	nMOS	$V_{DS} = 60 \text{ В}; I_D = 150 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; g_f = 100 \text{ мСм}; R_{DS(on)} = 5 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
MCs	BFS17P	SIEM	npn	$V_{CE} = 25 \text{ В}; I_C = 25 \text{ мА}; P_D = 280 \text{ мВт}; h_{FE1} = 20...150; f_T = 2500 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
MCs	BFS17W	SIEM	npn	$V_{CE} = 25 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 280 \text{ мВт}; h_{FE1} = 20...150; f_T > 2500 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	B-E-C
MD	2SA1052D	REN	npn	$V_{CE} = 30 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} = 250...500$	SOT23, SOD23	B-E-C
MD	2SA2080D	REN	npn	$V_{CE} = 30 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE1} = 250...500$	SOT23, SC70	B-E-C
MF	ZVN3310F	ZETEX	nMOS	$V_{DS} = 100 \text{ В}; I_D = 100 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; g_f = 150 \text{ мСм}; R_{DS(on)} = 5 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
MH	M1MA141KT	MOT	di	$V_R < 40 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOT323, SC70	A-n.c.-K
MH	M1MA151KT	MOT	di	$V_R < 40 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
MI	M1MA142KT	MOT	di	$V_R < 80 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOT323, SC70	A-n.c.-K
MI	M1MA152KT	MOT	di	$V_R < 80 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOT346, SC59	A-n.c.-K
MAJ1	MMBD355LT1	MOT	shd-2	$V_R > 7 \text{ В}; V_{FI}(I_R = 10 \text{ мА}) < 0.6 \text{ В}; C_0 < 1 \text{ пФ}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
ML	ZVP3306F	ZETEX	pMOS	$V_{DS} = 60 \text{ В}; I_D = 90 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; g_f = 25 \text{ мСм}; R_{DS(on)} = 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
MN	M1MA141WA	MOT	di-2	$V_R < 40 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOT323, SC70	K1-K2-A1, A2
MN	M1MA151WA	MOT	di-2	$V_R < 40 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOT346, SC59	K1-K2-A1, A2
MO	M1MA142WA	MOT	di-2	$V_R < 80 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOT323, SC70	K1-K2-A1, A2
MO	M1MA152WA	MOT	di-2	$V_R < 80 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOT346, SC59	K1-K2-A1, A2
MR	ZVP3310F	ZETEX	pMOS	$V_{DS} = 100 \text{ В}; I_D = 45 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; g_f = 60 \text{ мСм}; R_{DS(on)} = 14 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
MT	M1MA141WK	MOT	di-2	$V_R < 40 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOT323, SC70	A1-A2-K1, K2
MT	M1MA151WK	MOT	di-2	$V_R < 40 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOT346, SC59	A1-A2-K1, K2
MT	ZVP1320F	ZETEX	pMOS	$V_{DS} = 200 \text{ В}; I_D = 35 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; g_f = 150 \text{ мСм}; R_{DS(on)} = 2.5 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
MTT	ADM1812-10AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 4.35 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC}; \overline{\text{RST}}; \text{GND}$
MTT	ADM1812-10ART	AD	mrc	$V_{TR} = 4.35 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$\overline{\text{RST}}; V_{CC}; \text{GND}$
MTV	ADM1812-5AKS	AD	mrc	$V_{TR} = 4.62 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT323, SC70	$V_{CC}; \overline{\text{RST}}; \text{GND}$
MTV	ADM1812-SART	AD	mrc	$V_{TR} = 4.62 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	$\overline{\text{RST}}; V_{CC}; \text{GND}$
MU	M1MA142WK	MOT	di-2	$V_R < 80 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOT323, SC70	A1-A2-K1, K2
MU	M1MA152WK	MOT	di-2	$V_R < 80 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}$	SOT346, SC59	A1-A2-K1, K2
MV	ZVN3320F	ZETEX	nMOS	$V_{DS} = 200 \text{ В}; I_D = 60 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; g_f = 100 \text{ мСм}; R_{DS(on)} = 10 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
MV	1SV272	SANYO	pin	$V_D = 50 \text{ В}; I_D < 100 \text{ мА}; V_{FI}(I_D = 100 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; I_R < 0.5 \text{ мкА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
MV	BS170F	ZETEX	nMOS	$V_{DS} = 60 \text{ В}; I_D = 150 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	G-S-D
MX	BS250F	ZETEX	pMOS	$V_{DS} = 45 \text{ В}; I_D = 90 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; g_f = 200 \text{ мСм}; R_{DS(on)} = 5 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
MY	VN10LF	ZETEX	nMOS	$V_{DS} = 60 \text{ В}; I_D = 150 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	G-S-D



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
MZ	ZVN4106F	ZETEX	nMOS	$V_{DS} < 60 \text{ В}; I_D < 200 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; g_m = 75 \text{ мСм}; R_{DS(on)} = 25 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G•S•D
MZT	ADM1810-10AKS	AD	mrc	$V_{DS} = 4.35 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
MZT	ADM1810-10ART	AD	mrc	$V_{DS} = 4.35 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
MZV	ADM1810-5AKS	AD	mrc	$V_{DS} = 4.62 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT323, SC70	V_{CC} -RST-GND
MZV	ADM1810-5ART	AD	mrc	$V_{DS} = 4.62 \text{ В}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 16 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	RST- V_{CC} -GND
N	BAV70	VISH	di-2	$V_A = 70 \text{ В}; I_F < 300 \text{ мА}; V_F(I_F = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_R < 5.0 \text{ мА}; C_J < 4.0 \text{ пФ}; I_{RRM} < 6 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
N	DAN202K	ROHM	di-2	$V_A < 80 \text{ В}; I_F < 300 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; V_F(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}; I_{RRM} < 4 \text{ нС}$	SOT346, SC59	A1•A2•K1, K2
N	DAN202U	ROHM	di-2	$V_A < 80 \text{ В}; I_F < 300 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; V_F(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}; I_{RRM} < 4 \text{ нС}$	SOT323, SC70	A1•A2•K1, K2
N	DAN222	ROHM	di-2	$V_A < 80 \text{ В}; I_F < 300 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; V_F(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}; I_{RRM} < 4 \text{ нС}$	SOT416, SC75A	A1•A2•K1, K2
N	DAN222M	ROHM	di-2	$V_A < 80 \text{ В}; I_F < 300 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; V_F(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}; I_{RRM} < 4 \text{ нС}$	VMT3, VMD3	A1•A2•K1, K2
N0	TN0200T	SIL	nMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 730 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; I_{BSS} = 8...20 \text{ мА}; g_m = 4 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	G•S•D
N0	TN0200T	NS	nMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 730 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; I_{BSS} = 8...20 \text{ мА}; g_m = 4 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	G•S•D
N01	DDTC113TCA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_1 \text{ 1 к}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N01	DDTC113TE	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; R_1 \text{ 1 к}$	SOT523	B•E•C
N01	DDTC113TKA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_1 \text{ 1 к}$	SOT346, SC59	B•E•C
N01	DDTC113TUA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_1 \text{ 1 к}$	SOT323, SC70	B•E•C
N02	DDTC113ZCA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 1 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N02	DDTC113ZE	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; 1 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT523	B•E•C
N02	DDTC113ZKA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 1 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT346, SC59	B•E•C
N02	DDTC113ZUA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 1 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT323, SC70	B•E•C
N03	DDTC123TCA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_1 \text{ 2,2 к}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N03	DDTC123TE	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; R_1 \text{ 2,2 к}$	SOT523	B•E•C
N03	DDTC123TKA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_1 \text{ 2,2 к}$	SOT346, SC59	B•E•C
N03	DDTC123TUA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_1 \text{ 2,2 к}$	SOT323, SC70	B•E•C
N04	DDTC123ECA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 2,2 \text{ к}/2,2 \text{ к}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N04	DDTC123EE	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; 2,2 \text{ к}/2,2 \text{ к}$	SOT523	B•E•C
N04	DDTC123EKA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 2,2 \text{ к}/2,2 \text{ к}$	SOT346, SC59	B•E•C
N04	DDTC123EUA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 2,2 \text{ к}/2,2 \text{ к}$	SOT323, SC70	B•E•C
N05	DDTC123YCA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 2,2 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N05	DDTC123YE	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; 2,2 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT523	B•E•C
N05	DDTC123YKA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 2,2 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT346, SC59	B•E•C
N05	DDTC123YUA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 2,2 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT323, SC70	B•E•C
N05	SOZ84A	SGS	nnpn	$V_{DS} = 60 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N06	DDTC123JCA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 2,2 \text{ к}/47 \text{ к}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N06	DDTC123JE	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; 2,2 \text{ к}/47 \text{ к}$	SOT523	B•E•C
N06	DDTC123JKA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 2,2 \text{ к}/47 \text{ к}$	SOT346, SC59	B•E•C
N06	DDTC123JUA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 2,2 \text{ к}/47 \text{ к}$	SOT323, SC70	B•E•C
N07	DDTC143TCA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_1 \text{ 4,7 к}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N07	DDTC143TE	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; R_1 \text{ 4,7 к}$	SOT523	B•E•C
N07	DDTC143TKA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_1 \text{ 4,7 к}$	SOT346, SC59	B•E•C
N07	DDTC143TUA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_1 \text{ 4,7 к}$	SOT323, SC70	B•E•C
N08	DDTC143ECA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 4,7 \text{ к}/4,7 \text{ к}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N08	DDTC143EE	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; 4,7 \text{ к}/4,7 \text{ к}$	SOT523	B•E•C
N08	DDTC143EKA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 4,7 \text{ к}/4,7 \text{ к}$	SOT346, SC59	B•E•C
N08	DDTC143EUA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 4,7 \text{ к}/4,7 \text{ к}$	SOT323, SC70	B•E•C
N08	SO930	SGS	nnpn	$V_{DS} = 45 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE} < 600; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N09	DDTC123XCA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 4,7 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N09	DDTC123XE	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; 4,7 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT523	B•E•C
N09	DDTC123XKA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 4,7 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT346, SC59	B•E•C
N09	DDTC123XUA	DIODS	Dnnpn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 4,7 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT323, SC70	B•E•C
N1	MMBF201N	MOT	nMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	G•S•D

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3
VMD3



SOT416
SOT523

SOT323
SOT346

SOT23-3
SOD23-3



Код	Типоминал	FAIR	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
N1	MMBT100	FAIR	npn	$V_{CEB} = 75 В; I_C = 500 мА; P_D = 350 мВт; \eta_{21} = 450; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N1	TN0201T	SIL	nMOS	$V_{DS} = 20 В; I_D = 390 мА; P_D = 350 мВт; g_{fs} = 450 мСм; R_{DS(on)} = 0.75 Ом$	SOT23, SOD23	Г-Б-Д
N1	TN0201T	TEMIC	nMOS	$V_{DS} = 20 В; I_D = 390 мА; P_D = 350 мВт; g_{fs} = 450 мСм; R_{DS(on)} = 0.75 Ом$	SOT23, SOD23	Г-Б-Д
N10	DDTC143FCA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/22 к$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N10	DDTC143FE	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 4.7 к/22 к$	SOT523	В-Е-С
N10	DDTC143FKA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/22 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
N10	DDTC143FUJA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/22 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
N10	SO918	SGS	npn	$V_{CEB} = 15 В; I_C = 30 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 600 МГц$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N11	DDTC143ZCA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/47 к$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N11	DDTC143ZE	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 4.7 к/47 к$	SOT523	В-Е-С
N11	DDTC143ZKA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/47 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
N11	DDTC143ZUA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/47 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
N11	SO2369	SGS	npn	$V_{CEB} = 40 В; I_C = 200 мА; P_D = 200 мВт; \eta_{21} = 40; \dots 120; f_T > 400 МГц$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N12	DDTC114TCA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; R1 10 к$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N12	DDTC114TE	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; R1 10 к$	SOT523	В-Е-С
N12	DDTC114TKA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; R1 10 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
N12	DDTC114TUA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; R1 10 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
N12	SO2221	SGS	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_C = 800 мА; P_D = 310 мВт; \eta_{21} = 40; \dots 120; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N12	TMP72221	ALLEG	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_{CBO} < 10 мА; \eta_{21} = 40; \dots 120; V_{CE(sat)} < 0.4 В; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N13	DDTC114ECA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/10 к$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N13	DDTC114EE	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 10 к/10 к$	SOT523	В-Е-С
N13	DDTC114EKA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/10 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
N13	DDTC114EUA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/10 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
N13	SO2222	SGS	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_C = 800 мА; P_D = 310 мВт; \eta_{21} = 100; \dots 300; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N14	DDTC114YCA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/47 к$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N14	DDTC114YE	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 10 к/47 к$	SOT523	В-Е-С
N14	DDTC114YKA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/47 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
N14	DDTC114YUA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/47 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
N15	DDTC114WCA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/4.7 к$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N15	DDTC114WE	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 10 к/4.7 к$	SOT523	В-Е-С
N15	DDTC114WKA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/4.7 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
N15	DDTC114WUA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/4.7 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
N16	DDTC124TCA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; R; 22 к$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N16	DDTC124TE	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; R; 22 к$	SOT523	В-Е-С
N16	DDTC124TKA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; R; 22 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
N16	DDTC124TUA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; R; 22 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
N17	DDTC124ECA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 22 к/22 к$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N17	DDTC124EE	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 22 к/22 к$	SOT523	В-Е-С
N17	DDTC124EKA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 22 к/22 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
N17	DDTC124EUA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 22 к/22 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
N18	DDTC124XCA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 22 к/47 к$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N18	DDTC124XE	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 22 к/47 к$	SOT523	В-Е-С
N18	DDTC124XKA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 22 к/47 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
N18	DDTC124XUA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 22 к/47 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
N18	SO1711	SGS	npn	$V_{CEB} = 75 В; I_C = 800 мА; P_D = 310 мВт; \eta_{21} > 35; f_T > 70 МГц$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N19	DDTC144TCA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; R; 47 к$	SOT23, SOD23	В-Е-С
N19	DDTC144TE	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; R; 47 к$	SOT523	В-Е-С
N19	DDTC144TKA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; R; 47 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
N19	DDTC144TUA	DIODS	Dnnp	$V_{OC} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; R; 47 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
N2	BFSS20	PHIL	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 70 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 60; \dots 200; f_T = 9 ГГц$	SOT323, SC70	В-Е-С
N2	MGSF1N02LT1	ON	nMOS	$V_{DS} = 20 В; I_D = 750 мА; P_D = 400 мВт; R_{DS(on)} < 0.13 Ом$	SOT23, SOD23	Г-Б-Д
N2	MMBC1653N2	MOT	npn	$V_{CEB} = 150 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 50; \dots 130$	SOT23, SOD23	В-Е-С



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPAK TSFP-3 VMD3

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3
N20	DDTC144ECA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 47 \text{ к}/47 \text{ к}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N20	DDTC144EE	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; 47 \text{ к}/47 \text{ к}$	SOT523	В•Е•С
N20	DDTC144EKA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 47 \text{ к}/47 \text{ к}$	SOT346, SC59	В•Е•С
N20	DDTC144EUA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 47 \text{ к}/47 \text{ к}$	SOT323, SC70	В•Е•С
N20	SO2222A	SGS	nprn	$V_{CE(sat)} = 75 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 310 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N21	DDTC144VCA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 47 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N21	DDTC144VE	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; 47 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT523	В•Е•С
N21	DDTC144VKA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 47 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT346, SC59	В•Е•С
N21	DDTC144VUA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 47 \text{ к}/10 \text{ к}$	SOT323, SC70	В•Е•С
N22	DDTC144WCA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 47 \text{ к}/22 \text{ к}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N22	DDTC144WE	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; 47 \text{ к}/22 \text{ к}$	SOT523	В•Е•С
N22	DDTC144WKA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 47 \text{ к}/22 \text{ к}$	SOT346, SC59	В•Е•С
N22	DDTC144WUA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 47 \text{ к}/22 \text{ к}$	SOT323, SC70	В•Е•С
N23	DDTC115TCA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_1 = 100 \text{ к}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N23	DDTC115TE	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; R_1 = 100 \text{ к}$	SOT523	В•Е•С
N23	DDTC115TKA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_1 = 100 \text{ к}$	SOT346, SC59	В•Е•С
N23	DDTC115TUA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_1 = 100 \text{ к}$	SOT323, SC70	В•Е•С
N24	DDTC115ECA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 100 \text{ к}/100 \text{ к}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N24	DDTC115EE	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; 100 \text{ к}/100 \text{ к}$	SOT523	В•Е•С
N24	DDTC115EKA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 100 \text{ к}/100 \text{ к}$	SOT346, SC59	В•Е•С
N24	DDTC115EUA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 100 \text{ к}/100 \text{ к}$	SOT323, SC70	В•Е•С
N25	DDTC125TCA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_1 = 200 \text{ к}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N25	DDTC125TE	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; R_1 = 200 \text{ к}$	SOT523	В•Е•С
N25	DDTC125TKA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_1 = 200 \text{ к}$	SOT346, SC59	В•Е•С
N25	DDTC125TUA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_1 = 200 \text{ к}$	SOT323, SC70	В•Е•С
N26	DDTC114GCA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R2 = 10 \text{ к}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N26	DDTC114GE	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; R2 = 10 \text{ к}$	SOT523	В•Е•С
N26	DDTC114GKA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R2 = 10 \text{ к}$	SOT346, SC59	В•Е•С
N26	DDTC114GUA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R2 = 10 \text{ к}$	SOT323, SC70	В•Е•С
N27	DDTC124GCA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_2 = 22 \text{ к}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N27	DDTC124GE	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; R_2 = 22 \text{ к}$	SOT523	В•Е•С
N27	DDTC124GKA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; R_2 = 22 \text{ к}$	SOT346, SC59	В•Е•С
N27	DDTC124GUA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; R_2 = 22 \text{ к}$	SOT323, SC70	В•Е•С
N27	SO1893	SGS	nprn	$V_{CE(sat)} = 120 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 310 \text{ мВт}; h_{FE1} = 40...120; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N28	DDTC144GCA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_2 = 47 \text{ к}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N28	DDTC144GE	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; R_2 = 47 \text{ к}$	SOT523	В•Е•С
N28	DDTC144GKA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_2 = 47 \text{ к}$	SOT346, SC59	В•Е•С
N28	DDTC144GUA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_2 = 47 \text{ к}$	SOT323, SC70	В•Е•С
N28	SO3572	SGS	nprn	$V_{CE(sat)} = 15 \text{ В}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T > 1 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N29	DDTC115GCA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_2 = 100 \text{ к}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N29	DDTC115GE	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; R_2 = 100 \text{ к}$	SOT523	В•Е•С
N29	DDTC115GKA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_2 = 100 \text{ к}$	SOT346, SC59	В•Е•С
N29	DDTC115GUA	DIODS	Dnprn	$V_{CC} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R_2 = 100 \text{ к}$	SOT323, SC70	В•Е•С
N3	KDV152S	KEC	bd	$V_A = 15 \text{ В}; I_A = 50 \text{ мА}; C2 \text{ B} = 45 \text{ нФ}; C_{GB} = 26 \text{ нФ}; R_{GS} < 0.3 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•n.c. •K
N3	MGSF1N03LT1	ON	nMOS	$V_{DS} = 30 \text{ В}; I_D = 1.5 \text{ А}; P_D = 420 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 0.145 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G•S•D
N3	MMBC1653N3	MOT	nprn	$V_{CE(sat)} = 150 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...220$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N4	MMBC1653N4	MOT	nprn	$V_{CE(sat)} = 150 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{FE1} = 150...330$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N44	SO3571	SGS	nprn	$V_{CE(sat)} = 15 \text{ В}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T > 1.2 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N47	SO3570	SGS	nprn	$V_{CE(sat)} = 15 \text{ В}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T > 1.5 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N5	MMBC1654N5	MOT	nprn	$V_{CE(sat)} = 180 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{FE1} = 50...130$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N54	SO2221A	SGS	nprn	$V_{CE(sat)} = 75 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 310 \text{ мВт}; h_{FE1} = 40...120; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
N54	TMPT2221A	ALLEG	nprn	$V_{CE(sat)} = 75 \text{ В}; I_{CB} < 10 \text{ мА}; h_{FE1} = 40...120; V_{CE(sat)} < 0.3 \text{ В}; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
N6	BFS25A	PHIL	npn	$I_C < 6.5 \text{ mA}; P_D < 32 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T < 5.5 \text{ ГГц}$	SOT323, SC70	B•E•C
N6	MMBC1654N6	MOT	npn	$V_{CEB} < 180 \text{ В}; I_C < 50 \text{ mA}; P_D < 300 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100 \dots 220$	SOT23, SOD23	B•E•C
N7	MMBC1654N7	MOT	npn	$V_{CEB} < 180 \text{ В}; I_C < 50 \text{ mA}; P_D < 300 \text{ мВт}; h_{FE1} > 150 \dots 330$	SOT23, SOD23	B•E•C
N71	SO3904	SGS	npn	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_C < 200 \text{ mA}; P_D < 300 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100 \dots 300; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N72	SO3903	SGS	npn	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_C < 200 \text{ mA}; P_D < 300 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50 \dots 150; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N79	SO5550	SGS	npn	$V_{CEB} < 160 \text{ В}; I_C < 600 \text{ mA}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 60 \dots 250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N80	SO5551	SGS	npn	$V_{CEB} < 180 \text{ В}; I_C < 600 \text{ mA}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 80 \dots 250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N81	SO2369A	SGS	npn	$V_{CEB} < 40 \text{ В}; I_C < 200 \text{ mA}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40 \dots 120; f_T > 500 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N9	ISS372	TOSH	shd-2	$V_R < 10 \text{ В}; I_C < 100 \text{ mA}; V_{FE}(I_C = 100 \text{ mA}) < 0.5 \text{ В}; C_D < 40 \text{ пФ}$	SOT323, SC70	A1•K2•K1, A2
N9	1SS374	TOSH	shd-2	$V_R < 10 \text{ В}; V_{FE}(I_C = 100 \text{ mA}) < 0.5 \text{ В}; I_{B1}(V_{R1} = 10 \text{ В}) < 20 \text{ мкА}; C_T < 40 \text{ пФ}$	SOT346, SC59	A1•K2•K1, A2
N9	DAN222	ON	di-2	$V_R < 80 \text{ В}; I_C < 300 \text{ mA}; P_D < 150 \text{ мВт}; V_{FE}(I_C = 100 \text{ mA}) < 1.2 \text{ В}; t_{BCK} < 4 \text{ нс}$	SOT416, SOT75A	A1•A2•K1, K2
N91	SO642	SGS	npn	$V_{CEB} < 300 \text{ В}; I_C < 100 \text{ mA}; P_D < 310 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
N94	SO517	SGS	dnnp	$V_{CEB} < 40 \text{ В}; I_C < 400 \text{ mA}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{FE1} > 30000; f_T > 220 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
NA	FMMTA05R	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_C < 500 \text{ mA}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
NA	KRC401	KEC	npn	$V_{CEB} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ mA}; P_D < 100 \text{ мВт}; R_1/R_2 < 4.7/4.7 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B•E•C
NA	RN1443A	TOSH	Dnpn	$V_{CEB} < 50 \text{ В}; I_C < 300 \text{ mA}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 200 \dots 700; f_T < 30 \text{ МГц}; R_1 < 22 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B•E•C
NA1	MMBT100A	FAIR	npn	$V_{CEB} < 75 \text{ В}; I_C < 500 \text{ mA}; P_D < 350 \text{ мВт}; h_{FE1} > 600; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
NB	BF599	SIEM	npn	$V_{CEB} < 40 \text{ В}; I_C < 25 \text{ mA}; P_D < 280 \text{ мВт}; h_{FE1} > 38; f_T < 550 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
NB	DAP222U	ON	di-2	$V_R < 80 \text{ В}; I_C < 300 \text{ mA}; P_D < 150 \text{ мВт}; V_{FE}(I_C = 100 \text{ mA}) < 1.2 \text{ В}; t_{BCK} < 4 \text{ нс}$	SOT323, SC70	K1•K2•A1, A2
NB	FMMTA55R	ZETEX	npn	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_C < 500 \text{ mA}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
NB	KRC402	KEC	npn	$V_{CEB} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ mA}; P_D < 100 \text{ мВт}; R_1/R_2 < 10/10 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B•E•C
NB	RN1443B	TOSH	Dnpn	$V_{CEB} < 50 \text{ В}; I_C < 300 \text{ mA}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 350 \dots 1200; f_T < 30 \text{ МГц}; R_1 < 22 \text{ кОм}$	SOT346, SC59	B•E•C
NC	BF840	CDIL	npn	$V_{CEB} < 40 \text{ В}; I_C < 25 \text{ mA}; P_D < 280 \text{ мВт}; h_{FE1} > 65 \dots 220; f_T > 380 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
NC	BF840	SIEM	npn	$V_{CEB} < 40 \text{ В}; I_C < 25 \text{ mA}; P_D < 280 \text{ мВт}; h_{FE1} > 65 \dots 220; f_T > 380 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
NC	KRC403	KEC	npn	$V_{CEB} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ mA}; P_D < 100 \text{ мВт}; R_1/R_2 < 22/22 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B•E•C
NCp	BF840	PHIL	npn	$V_{CEB} < 40 \text{ В}; I_C < 25 \text{ mA}; P_D < 250 \text{ мВт}; I_B < 4.5 \dots 15 \text{ мкА}; f_T < 380 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
ND	2SD1306D	REN	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 700 \text{ mA}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 250 \dots 500$	SOT23, SOD23	B•E•C
ND	BF841	CDIL	npn	$V_{CEB} < 40 \text{ В}; I_C < 25 \text{ mA}; P_D < 280 \text{ мВт}; h_{FE1} > 35 \dots 125; f_T > 380 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
ND	BF841	SIEM	npn	$V_{CEB} < 40 \text{ В}; I_C < 25 \text{ mA}; P_D < 280 \text{ мВт}; h_{FE1} > 35 \dots 125; f_T > 380 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
ND	KRC404	KEC	npn	$V_{CEB} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ mA}; P_D < 100 \text{ мВт}; R_1/R_2 < 47/47 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B•E•C
NDp	BF841	PHIL	npn	$V_{CEB} < 40 \text{ В}; I_C < 25 \text{ mA}; P_D < 250 \text{ мВт}; I_B < 8 \dots 28 \text{ мкА}; f_T < 380 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
NE	2SD1306E	REN	npn	$V_{CEB} < 30 \text{ В}; I_C < 700 \text{ mA}; P_D < 150 \text{ мВт}; h_{FE1} > 400 \dots 800$	SOT23, SOD23	B•E•C
NE	KRC405	KEC	npn	$V_{CEB} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ mA}; P_D < 100 \text{ мВт}; R_1/R_2 < 2.2/47 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B•E•C
NF	KRC406	KEC	npn	$V_{CEB} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ mA}; P_D < 100 \text{ мВт}; R_1/R_2 < 4.7/47 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B•E•C
NK	KRC410	KEC	npn	$V_{CEB} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ mA}; P_D < 100 \text{ мВт}; R_1 < 4.7 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B•E•C
NM	KRC411	KEC	npn	$V_{CEB} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ mA}; P_D < 100 \text{ мВт}; R_1 < 10 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B•E•C
NN	KRC412	KEC	npn	$V_{CEB} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ mA}; P_D < 100 \text{ мВт}; R_1 < 100 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B•E•C
NO	KRC413	KEC	npn	$V_{CEB} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ mA}; P_D < 100 \text{ мВт}; R_1 < 22 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B•E•C
NP	KRC414	KEC	npn	$V_{CEB} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ mA}; P_D < 100 \text{ мВт}; R_1 < 47 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B•E•C
NS	TN0200T5	SIL	nMOS	$V_{DS} < 20 \text{ В}; I_D < 1200 \text{ mA}; P_D < 1000 \text{ мВт}; g_{FS} < 2200 \text{ мСм}; R_{DS(on)} < 0.4 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G•S•D
O05	SO2484R	SGS	npn	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_C < 200 \text{ mA}; P_D < 200 \text{ мВт}; f_T > 60 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	E•B•C
O08	SO930R	SGS	npn	$V_{CEB} < 45 \text{ В}; I_C < 30 \text{ mA}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	E•B•C
O10	SO918R	SGS	npn	$V_{CEB} < 15 \text{ В}; I_C < 30 \text{ mA}; P_D < 200 \text{ мВт}; f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	E•B•C
O12	SO2221R	SGS	npn	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_C < 800 \text{ mA}; P_D < 310 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40 \dots 120; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	E•B•C
O13	SO2222R	SGS	npn	$V_{CEB} < 60 \text{ В}; I_C < 800 \text{ mA}; P_D < 310 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100 \dots 300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	E•B•C
O20	SO2222AR	SGS	npn	$V_{CEB} < 75 \text{ В}; I_C < 800 \text{ mA}; P_D < 310 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100 \dots 300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	E•B•C
O27	SO1893R	SGS	npn	$V_{CEB} < 120 \text{ В}; I_C < 800 \text{ mA}; P_D < 310 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40 \dots 120; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	E•B•C
O54	SO2221AR	SGS	npn	$V_{CEB} < 75 \text{ В}; I_C < 800 \text{ mA}; P_D < 310 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40 \dots 120; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	E•B•C
O79	SO5550R	SGS	npn	$V_{CEB} < 160 \text{ В}; I_C < 600 \text{ mA}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 60 \dots 250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	E•B•C
O80	SO5551R	SGS	npn	$V_{CEB} < 180 \text{ В}; I_C < 600 \text{ mA}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 80 \dots 250; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	E•B•C
O9	1SS377	TOSH	shd-2	$V_R < 10 \text{ В}; V_{FE}(I_C = 100 \text{ mA}) < 0.5 \text{ В}; I_{B1}(V_{R1} = 10 \text{ В}) < 20 \text{ мкА}; C_T < 40 \text{ пФ}$	SOT346, SC59	A1•A2•K1, K2
O9	1SS378	TOSH	shd-2	$V_R < 10 \text{ В}; I_C < 100 \text{ mA}; V_{FE}(I_C = 100 \text{ mA}) < 0.5 \text{ В}; C_D < 20 \text{ пФ}$	SOT323, SC70	A1•A2•K1, K2



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
O9	1SS379	TOSH	di-2	$V_{BE} < 80 В; I_{C1} < 100 мА; V_{CE}(I_{C1}) < 1.3 В; I_{B1} < 0.01 мА$	SOT346,SC59	A1•K2•K1,A2
O9	1SS385	TOSH	shd-2	$V_{BE} < 10 В; V_{CE}(I_{C1}) < 0.5 В; I_{B1}(V_{BE} > 10 В) < 20 мкА; C_T < 20 пФ$	SOT416,SC75A	A1•A2•K1,K2
O9	1SS385F	TOSH	shd-2	$V_{BE} < 10 В; V_{CE}(I_{C1}) < 0.5 В; I_{B1}(V_{BE} > 10 В) < 20 мкА; C_T < 20 пФ$	SOT490,SC89	A1•A2•K1,K2
O91	SO642R	SGS	pnп	$V_{CE(sat)} < 300 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 310 мВт; h_{FE1} > 40; f_T > 50 МГц$	SOT23,SOD23	E•B•C
P	BAW56	WISH	di-2	$V_{BE} < 70 В; I_{C1} < 300 мА; V_{CE}(I_{C1}) < 1.25 В; I_{B1} < 5.0 мкА; C_{C0} < 4.0 пФ; t_{berr} < 6 нс$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1,A2
P	DAP202K	ROHM	di-2	$V_{BE} < 80 В; I_{C1} < 300 мА; P_D < 200 мВт; V_{CE}(I_{C1}) < 1.2 В; t_{berr} < 4 нс$	SOT346,SC59	K1•K2•A1,A2
P	DAP202U	ROHM	di-2	$V_{BE} < 80 В; I_{C1} < 300 мА; P_D < 200 мВт; V_{CE}(I_{C1}) < 1.2 В; t_{berr} < 4 нс$	SOT323,SC70	K1•K2•A1,A2
P	DAP222	ROHM	di-2	$V_{BE} < 80 В; I_{C1} < 300 мА; P_D < 150 мВт; V_{CE}(I_{C1}) < 1.2 В; t_{berr} < 4 нс$	SOT416,SC75A	K1•K2•A1,A2
P	DAP222M	ROHM	di-2	$V_{BE} < 80 В; I_{C1} < 300 мА; P_D < 150 мВт; V_{CE}(I_{C1}) < 1.2 В; t_{berr} < 4 нс$	VMT3,VMD3	K1•K2•A1,A2
P0	HSMS2850	HP	shd	$V_{BE}(I_{C1} = 1 мА) < 0.25 В; C_T < 0.3 пФ$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
P0	HSMS285B	HP	shd	$V_{BE}(I_{C1} = 1 мА) < 0.25 В; C_T < 0.3 пФ$	SOT323,SC70	A•n.c.•K
P0	TP0101T	SIIL	pMOS	$V_{DS} < 20 В; I_D < 600 мА; P_D < 350 мВт; g_m > 13000 мСм; R_{DS(on)} < 0.65 Ом$	SOT23,SOD23	G•S•D
P0	TP0101T	TEMIC	pMOS	$V_{DS} < 20 В; I_D < 600 мА; P_D < 350 мВт; g_m > 13000 мСм; R_{DS(on)} < 0.65 Ом$	SOT23,SOD23	G•S•D
P01	DDTA113TCA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; R_1 < 1 к$	SOT23,SOD23	B•E•C
P01	DDTA113TE	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 150 мВт; R_1 < 1 к$	SOT523	B•E•C
P01	DDTA113TKA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; R_1 < 1 к$	SOT346,SC59	B•E•C
P01	DDTA113TUA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; R_1 < 1 к$	SOT323,SC70	B•E•C
p01	PDTA143ET	PHIL	Dpnp	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{FE1} > 30; 4.7 кОм/4.7 кОм$	SOT23,SOD23	B•E•C
p01	PDTA143EU	PHIL	Dpnp	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{FE1} > 30; 4.7 кОм/4.7 кОм$	SOT323,SC70	B•E•C
P01	SO2906	SGS	pnп	$V_{CE(sat)} < 40 В; I_{C1} < 150 мА; P_D < 300 мВт; h_{FE1} > 40...120; f_T > 200 МГц$	SOT23,SOD23	B•E•C
P02	DDTA113ZCA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; 1 к/10 к$	SOT23,SOD23	B•E•C
P02	DDTA113ZE	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 150 мВт; 1 к/10 к$	SOT523	B•E•C
P02	DDTA113ZKA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; 1 к/10 к$	SOT346,SC59	B•E•C
P02	DDTA113ZUA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; 1 к/10 к$	SOT323,SC70	B•E•C
p02	PDTC143ET	PHIL	Dnpn	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{FE1} > 30; 4.7 кОм/4.7 кОм$	SOT23,SOD23	B•E•C
p02	PDTC143EU	PHIL	Dnpn	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{FE1} > 30; 4.7 кОм/4.7 кОм$	SOT323,SC70	B•E•C
P03	DDTA123TCA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; R1 < 2.2 к$	SOT23,SOD23	B•E•C
P03	DDTA123TE	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 150 мВт; R1 < 2.2 к$	SOT523	B•E•C
P03	DDTA123TKA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; R1 < 2.2 к$	SOT346,SC59	B•E•C
P03	DDTA123TUA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; R1 < 2.2 к$	SOT323,SC70	B•E•C
p03	PDTA114ET	PHIL	Dpnp	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; h_{FE1} > 30; 10 кОм/10 кОм$	SOT23,SOD23	B•E•C
P03	SO2907A	SGS	pnп	$V_{CE(sat)} < 60 В; I_{C1} < 200 мА; P_D < 300 мВт; h_{FE1} > 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT23,SOD23	B•E•C
P04	DDTA123ECA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; 2.2 к/2.2 к$	SOT23,SOD23	B•E•C
P04	DDTA123EE	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 150 мВт; 2.2 к/2.2 к$	SOT523	B•E•C
P04	DDTA123EKA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; 2.2 к/2.2 к$	SOT346,SC59	B•E•C
P04	DDTA123EUA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; 2.2 к/2.2 к$	SOT323,SC70	B•E•C
p04	PMSS3904	PHIL	pnп	$V_{CE(sat)} < 60 В; I_{C1} < 200 мА; P_D < 300 мВт; h_{FE1} > 100...300; f_T > 180 МГц$	SOT23,SOD23	B•E•C
P05	DDTA123YCA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; 2.2 к/10 к$	SOT23,SOD23	B•E•C
P05	DDTA123YE	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 150 мВт; 2.2 к/10 к$	SOT523	B•E•C
P05	DDTA123YKA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; 2.2 к/10 к$	SOT346,SC59	B•E•C
P05	DDTA123YUA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; 2.2 к/10 к$	SOT323,SC70	B•E•C
p05	PDTA124ET	PHIL	Dpnp	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_{C1} < 30 мА; P_D < 250 мВт; h_{FE1} > 56$	SOT23,SOD23	B•E•C
p05	PDTA124ET	PHIL	Dpnp	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{FE1} > 60; 22 кОм/22 кОм$	SOT23,SOD23	B•E•C
p05	PDTA124EU	PHIL	Dpnp	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{FE1} > 60; 22 кОм/22 кОм$	SOT323,SC70	B•E•C
P05	SO2907	SGS	pnп	$V_{CE(sat)} < 40 В; I_{C1} < 200 мА; P_D < 300 мВт; h_{FE1} > 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT23,SOD23	B•E•C
P06	DDTA123JCA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; 2.2 к/47 к$	SOT23,SOD23	B•E•C
P06	DDTA123JE	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 150 мВт; 2.2 к/47 к$	SOT523	B•E•C
P06	DDTA123JKA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; 2.2 к/47 к$	SOT346,SC59	B•E•C
P06	DDTA123JUA	DIODS	Dpnp	$V_{CE} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 200 мВт; 2.2 к/47 к$	SOT323,SC70	B•E•C
p06	PDTC124EU	PHIL	Dnpn	$V_{CE(sat)} < 50 В; I_{C1} < 100 мА; P_D < 250 мВт; h_{FE1} > 60; 22 кОм/22 кОм$	SOT323,SC70	B•E•C
p06	PMSS3906	PHIL	pnп	$V_{CE(sat)} < 40 В; I_{C1} < 200 мА; P_D < 200 мВт; h_{FE1} > 100...300; f_T > 150 МГц$	SOT23,SOD23	B•E•C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
p06	PMSS3906	PHIL	pnр	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 200 мА; P_D = 200 мВт; \eta_{21} = 100...300; f_T > 150 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
P06	SO2894	SGS	pnр	$V_{CE0} = 12 В; I_C = 200 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 40...150; f_T > 400 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
P07	DDTA143TCA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; R_{10} 1.4.7 к$	SOT323, SOD23	B-E-C
P07	DDTA143TE	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; R_{10} 1.4.7 к$	SOT523	B-E-C
P07	DDTA143TKA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; R_{10} 1.4.7 к$	SOT346, SC59	B-E-C
P07	DDTA143TUA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; R_{10} 1.4.7 к$	SOT323, SC70	B-E-C
p07	PDTA144ET	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; \eta_{21} > 80; 47 кОм/47 кОм$	SOT323, SOD23	B-E-C
p07	PDTA144EU	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; \eta_{21} > 80; 47 кОм/47 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
P08	DDTA143ECA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/4.7 к$	SOT323, SOD23	B-E-C
P08	DDTA143EE	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 4.7 к/4.7 к$	SOT523	B-E-C
P08	DDTA143EKA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; 4.7 к/4.7 к$	SOT346, SC59	B-E-C
P08	DDTA143EUA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/4.7 к$	SOT323, SC70	B-E-C
p08	PDTC144ET	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; \eta_{21} > 80; 47 кОм/47 кОм$	SOT323, SOD23	B-E-C
p08	PDTC144EU	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; \eta_{21} > 80; 47 кОм/47 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
P09	DDTA123XCA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/10 к$	SOT323, SOD23	B-E-C
P09	DDTA123XE	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 4.7 к/10 к$	SOT523	B-E-C
P09	DDTA123XKA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; 4.7 к/10 к$	SOT346, SC59	B-E-C
P09	DDTA123XUA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/10 к$	SOT323, SC70	B-E-C
p09	PDTB114ET	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; \eta_{21} > 56; 10 кОм/10 кОм$	SOT323, SOD23	B-E-C
p09	PDTC114EU	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 50 мА; P_D = 250 мВт; \eta_{21} > 30; 10 кОм/10 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
P1	BFR92	PHIL	pnр	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 25 мА; P_D = 273 мВт; \eta_{21} > 40; f_T > 4500 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
P1	BZX84C11T	DIODS	dz	$V_{Z(1zt) = 5.1 мА} = 10.4...11.6 В; Z_{T(1zt) = 5 мА} < 20 Ом$	SOT523	A-П.-С.-К
P1	SS201	SIL	nFET	$V_{GS} = 30 В; P_D = 350 мВт; I_{DSS} = 20...135 мА; R_{DS(on)} < 85 Ом$	SOT323, SOD23	D-S-G
P10	DDTA143FCA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/422 к$	SOT323, SOD23	B-E-C
P10	DDTA143FE	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 4.7 к/422 к$	SOT523	B-E-C
P10	DDTA143FKA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; 4.7 к/422 к$	SOT346, SC59	B-E-C
P10	DDTA143FUA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/422 к$	SOT323, SC70	B-E-C
p10	PDTD114ET	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; \eta_{21} > 56; 10 кОм/10 кОм$	SOT323, SOD23	B-E-C
P11	DDTA1432CA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/47 к$	SOT323, SOD23	B-E-C
P11	DDTA143ZE	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 4.7 к/47 к$	SOT523	B-E-C
P11	DDTA143ZKA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; 4.7 к/47 к$	SOT346, SC59	B-E-C
P11	DDTA143ZUA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 4.7 к/47 к$	SOT323, SC70	B-E-C
p11	PDTA114TT	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; \eta_{21} > 200; R_{10} 10 кОм$	SOT323, SOD23	B-E-C
P12	DDTA114TCA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; R_{10} 10 к$	SOT323, SOD23	B-E-C
P12	DDTA114TE	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; R_{10} 10 к$	SOT523	B-E-C
P12	DDTA114TKA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; R_{10} 10 к$	SOT346, SC59	B-E-C
P12	DDTA114TUA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; R_{10} 10 к$	SOT323, SC70	B-E-C
p12	PDTC114TT	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; \eta_{21} > 200; R_{10} 10 кОм$	SOT323, SOD23	B-E-C
P12	SO2906A	SGS	pnр	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 150 мА; P_D = 300 мВт; \eta_{21} = 40...120; f_T > 200 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
p13	BB207	PHIL	var-2	$V_{R0} = 15 В; I_{R0}(V_{R0} = 15 В) < 0.01 мкА; C_{1,2} = 76...86 пФ; C_{7,8} = 25.5...29.7 пФ$	SOT323, SOD23	A1-A2-K1,K2
P13	DDTA114ECA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/10 к$	SOT323, SOD23	B-E-C
P13	DDTA114EE	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 10 к/10 к$	SOT523	B-E-C
P13	DDTA114EKA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; 10 к/10 к$	SOT346, SC59	B-E-C
P13	DDTA114EUA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/10 к$	SOT323, SC70	B-E-C
P14	DDTA114YCA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; 10 к/47 к$	SOT323, SOD23	B-E-C
P14	DDTA114YE	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 10 к/47 к$	SOT523	B-E-C
P14	DDTA114YKA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; 10 к/47 к$	SOT346, SC59	B-E-C
P14	DDTA114YUA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; 10 к/47 к$	SOT323, SC70	B-E-C
P15	DDTA114WCA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/47 к$	SOT323, SOD23	B-E-C
P15	DDTA114WE	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 150 мВт; 10 к/47 к$	SOT523	B-E-C
P15	DDTA114WKA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; 10 к/47 к$	SOT346, SC59	B-E-C
P15	DDTA114WUA	DIODS	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D < 200 мВт; 10 к/47 к$	SOT323, SC70	B-E-C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типонаимал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
P16	DDTA124TCA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R1 \ 22 \ \text{k}$	SOT23, SOD23	B-E-C
P16	DDTA124TE	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; R1 \ 22 \ \text{k}$	SOT523	B-E-C
P16	DDTA124TKA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R1 \ 22 \ \text{k}$	SOT346, SC59	B-E-C
P16	DDTA124TUA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R1 \ 22 \ \text{k}$	SOT323, SC70	B-E-C
p16	PDTC114ET	PHIL	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 30; 10 \ \text{k}\Omega / 10 \ \text{k}\Omega \text{M}$	SOT23, SOD23	B-E-C
P17	DDTA124ECA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 22 \ \text{k} / 22 \ \text{k}$	SOT23, SOD23	B-E-C
P17	DDTA124EE	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; 22 \ \text{k} / 22 \ \text{k}$	SOT523	B-E-C
P17	DDTA124EKA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 22 \ \text{k} / 22 \ \text{k}$	SOT346, SC59	B-E-C
P17	DDTA124EUA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 22 \ \text{k} / 22 \ \text{k}$	SOT323, SC70	B-E-C
p17	PDTC124ET	PHIL	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 60; 22 \ \text{k}\Omega / 22 \ \text{k}\Omega \text{M}$	SOT23, SOD23	B-E-C
P17	DDTA124XCA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 22 \ \text{k} / 47 \ \text{k}$	SOT23, SOD23	B-E-C
P18	DDTA124XE	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; 22 \ \text{k} / 47 \ \text{k}$	SOT523	B-E-C
P18	DDTA124XKA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 22 \ \text{k} / 47 \ \text{k}$	SOT346, SC59	B-E-C
P18	DDTA124XUA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 22 \ \text{k} / 47 \ \text{k}$	SOT323, SC70	B-E-C
p18	PDTC1432T	PHIL	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 100; 4.7 \ \text{k}\Omega / 47 \ \text{k}\Omega \text{M}$	SOT23, SOD23	B-E-C
P19	DDTA144TCA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R1 \ 47 \ \text{k}$	SOT23, SOD23	B-E-C
P19	DDTA144TE	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; R1 \ 47 \ \text{k}$	SOT523	B-E-C
P19	DDTA144TKA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R1 \ 47 \ \text{k}$	SOT346, SC59	B-E-C
P19	DDTA144TUA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; R1 \ 47 \ \text{k}$	SOT323, SC70	B-E-C
p19	PDTA1432T	PHIL	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 100; 4.7 \ \text{k}\Omega / 47 \ \text{k}\Omega \text{M}$	SOT23, SOD23	B-E-C
p1A	PMBT3904	PHIL	nnp	$V_{CE} < 60 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 100 \dots 300; f_T > 300 \ \text{МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
p1A	PMST3904	PHIL	nnp	$V_{CE} < 60 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE} > 100 \dots 300; f_T > 300$	SOT323, SC70	B-E-C
p1B	PMBT2222	PHIL	nnp	$V_{CE} < 60 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 100 \dots 300; f_T > 250 \ \text{МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
p1D	PMBTA42	PHIL	nnp	$V_{CE} < 300 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 40; f_T > 50 \ \text{МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
p1E	PMBTA43	PHIL	nnp	$V_{CE} < 200 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 40; f_T > 50 \ \text{МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
p1F	PMBT5550	PHIL	nnp	$V_{CE} < 160 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 60 \dots 250; f_T > 100 \dots 300$	SOT23, SOD23	B-E-C
p1F	PMST5550	PHIL	nnp	$V_{CE} < 160 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE} > 60 \dots 250; f_T > 100 \dots 300$	SOT323, SC70	B-E-C
p1G	PMBTA06	PHIL	nnp	$V_{CE} < 80 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 50; f_T > 100 \ \text{МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
p1H	PMBTA05	PHIL	nnp	$V_{CE} < 60 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 50; f_T > 100 \ \text{МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
p1J	PMBT2369	PHIL	nnp	$V_{CE} < 40 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 40 \dots 120$	SOT23, SOD23	B-E-C
p1K	PMBT6428	PHIL	nnp	$V_{CE} < 60 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 250 \dots 650; f_T > 100 \dots 700 \ \text{МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
p1L	PMBT6429	PHIL	nnp	$V_{CE} < 55 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 500 \dots 1250; f_T > 100 \dots 700 \ \text{МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
p1M	PMBTA13	PHIL	dnpn	$V_{CE} < 30 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 5000; f_T > 125 \ \text{МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
p1N	PMBTA14	PHIL	dnpn	$V_{CE} < 30 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 10000; f_T > 125 \ \text{МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
p1P	PMBT2222A	PHIL	nnp	$V_{CE} < 75 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 100 \dots 300; f_T > 300 \ \text{МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
p1Q	PMBT5088	PHIL	nnp	$V_{CE} < 30 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 350 \dots 1400$	SOT23, SOD23	B-E-C
p1Q	PMST5088	PHIL	nnp	$V_{CE} < 35 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE} > 300 \dots 900$	SOT323, SC70	B-E-C
p1R	PMST5089	PHIL	nnp	$V_{CE} < 30 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; h_{FE} > 400 \dots 1200$	SOT323, SC70	B-E-C
P1s	BFR92W	SIEM	nnp	$V_{CE} < 20 \text{ В}; I_C < 30 \text{ мА}; P_D < 280 \text{ мВт}; h_{FE} > 40 \dots 200; f_T > 5000 \ \text{МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
P2	BFR92A	PHIL	nnp	$V_{CE} < 20 \text{ В}; I_C < 25 \text{ мА}; P_D < 273 \text{ мВт}; h_{FE} > 40; f_T > 4500 \ \text{МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
P2	BFR92ALT1	MOT	nnp	$V_{CE} < 20 \text{ В}; I_C < 25 \text{ мА}; P_D < 273 \text{ мВт}; h_{FE} > 40; f_T > 4500 \ \text{МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
P2	BZX84C12T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5 \ \text{мА}) = 11.4 \dots 12.7 \ \text{В}; Z_{T1}(I_{ZT} = 5 \ \text{мА}) < 25 \ \Omega$	SOT523	A-n.c.-K
P2	HSMS2852	HP	shd-2	$V_{FH}(I_F = 1 \ \text{мА}) < 0.25 \ \text{В}; C_T < 0.3 \ \text{пФ}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
P2	HSMS285C	HP	shd-2	$V_{FH}(I_F = 1 \ \text{мА}) < 0.25 \ \text{В}; C_T < 0.3 \ \text{пФ}$	SOT323, SC70	A1-K2-K1, A2
P2	SST202	SIL	nFET	$V_{DS} < 40 \ \text{В}; P_D < 350 \ \text{мВт}; I_{DSS} = 0.9 \dots 4.5 \ \text{мА}; g_m = 1 \ \text{мСМ}$	SOT23, SOD23	D-S-G
P20	DDTA144ECA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 47 \ \text{k} / 47 \ \text{k}$	SOT23, SOD23	B-E-C
P20	DDTA144EE	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; 47 \ \text{k} / 47 \ \text{k}$	SOT523	B-E-C
P20	DDTA144EKA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 47 \ \text{k} / 47 \ \text{k}$	SOT346, SC59	B-E-C
P20	DDTA144EUA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 47 \ \text{k} / 47 \ \text{k}$	SOT323, SC70	B-E-C
P21	DDTA144UCA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 47 \ \text{k} / 10 \ \text{k}$	SOT23, SOD23	B-E-C
P21	DDTA144VE	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 150 \text{ мВт}; 47 \ \text{k} / 10 \ \text{k}$	SOT523	B-E-C
P21	DDTA144VKA	DIODS	Dnnp	$V_{CE} < 50 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; 47 \ \text{k} / 10 \ \text{k}$	SOT346, SC59	B-E-C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
P21	DDTA144VJA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 47 к/10 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
P22	DDTA144WCA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 47 к/22 к$	SOT323, SOD23	В-Е-С
P22	DDTA144WE	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; 47 к/22 к$	SOT523	В-Е-С
P22	DDTA144WKA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 47 к/22 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
P22	DDTA144WUA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 47 к/22 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
P23	DDTA115TCA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R2 100 к$	SOT323, SOD23	В-Е-С
P23	DDTA115TE	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; R1 100 к$	SOT523	В-Е-С
P23	DDTA115TKA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R1 100 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
P23	DDTA115TUA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R1 100 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
p23	PDTA114TU	PHIL	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 200; R_1 10 кОм$	SOT323, SC70	В-Е-С
P24	DDTA115ECA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 100 к/100 к$	SOT323, SOD23	В-Е-С
P24	DDTA115EE	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; 100 к/100 к$	SOT523	В-Е-С
P24	DDTA115EKA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 100 к/100 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
P24	DDTA115EUA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; 100 к/100 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
p24	PDTCT114TU	PHIL	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 200; R_1 10 кОм$	SOT323, SC70	В-Е-С
P25	DDTA125TCA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R1 200 к$	SOT323, SOD23	В-Е-С
P25	DDTA125TE	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; R1 200 к$	SOT523	В-Е-С
P25	DDTA125TKA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R1 200 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
P25	DDTA125TUA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R1 200 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
P25	SO3906	SGS	npn	$V_{CEB}=40 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT323, SOD23	В-Е-С
P26	DDTA114GCA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R2 10 к$	SOT323, SOD23	В-Е-С
P26	DDTA114GE	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; R2 10 к$	SOT523	В-Е-С
P26	DDTA114GKA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R2 10 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
P26	DDTA114GUA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R2 10 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
P26	SO3905	SGS	npn	$V_{CEB}=40 В; I_C=200 мА; P_D=300 мВт; h_{21} = 50...150; f_T > 200 МГц$	SOT323, SOD23	В-Е-С
P27	DDTA124GCA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R2 22 к$	SOT323, SOD23	В-Е-С
P27	DDTA124GE	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; R2 22 к$	SOT523	В-Е-С
P27	DDTA124GKA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R2 22 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
P27	DDTA124GUA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R2 22 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
p27	PDTCT114YT	PHIL	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 100; 10 кОм/47 кОм$	SOT323, SOD23	В-Е-С
P28	DDTA144GCA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R2 47 к$	SOT323, SOD23	В-Е-С
P28	DDTA144GE	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; R2 47 к$	SOT523	В-Е-С
P28	DDTA144GKA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R2 47 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
P28	DDTA144GUA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R2 47 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
P29	DDTA115GCA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R2 100 к$	SOT323, SOD23	В-Е-С
P29	DDTA115GE	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 150 мВт; R2 100 к$	SOT523	В-Е-С
P29	DDTA115GKA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R2 100 к$	SOT346, SC59	В-Е-С
P29	DDTA115GUA	DIODS	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D < 200 мВт; R2 100 к$	SOT323, SC70	В-Е-С
p29	PDTA114YT	PHIL	Dnnp	$V_{CC}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; h_{21} > 100; 10 кОм/47 кОм$	SOT323, SOD23	В-Е-С
p2A	PMBT3906	PHIL	npn	$V_{CEB}=40 В; I_C=200 мА; P_D=250 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT323, SOD23	В-Е-С
p2A	PMBT3906	PHIL	npn	$V_{CEB}=40 В; I_C=200 мА; P_D=200 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT323, SC70	В-Е-С
p2B	PMBT2907	PHIL	npn	$V_{CEB}=60 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 30; f_T > 200 МГц$	SOT323, SOD23	В-Е-С
p2D	PMBTA92	PHIL	npn	$V_{CEB}=300 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 40; f_T > 50 МГц$	SOT323, SOD23	В-Е-С
p2E	PMBTA93	PHIL	npn	$V_{CEB}=200 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 40; f_T > 50 МГц$	SOT323, SOD23	В-Е-С
p2F	PMBT2907A	PHIL	npn	$V_{CEB}=60 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 50; f_T > 200 МГц$	SOT323, SOD23	В-Е-С
p2G	PMBTA56	PHIL	npn	$V_{CEB}=80 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 50; f_T > 50 МГц$	SOT323, SOD23	В-Е-С
p2H	PMBTA55	PHIL	npn	$V_{CEB}=60 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21} > 50; f_T > 50 МГц$	SOT323, SOD23	В-Е-С
p2L	PMBT5401	PHIL	npn	$V_{CEB}=160 В; I_C=500 мА; P_D=250 мВт; h_{21} = 60...240; f_T = 100...300 МГц$	SOT323, SOD23	В-Е-С
p2L	PMBT5401	PHIL	npn	$V_{CEB}=160 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{21} = 60...240; f_T = 100...300 МГц$	SOT323, SC70	В-Е-С
P2p	BFR92AW	PHIL	npn	$V_{CEB}=20 В; I_C=25 мА; P_D=273 мВт; h_{21} > 40; f_T=4500 МГц$	SOT323, SC70	В-Е-С
p2T	PMBT4403	PHIL	npn	$V_{CEB}=40 В; I_C=600 мА; P_D=250 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT323, SOD23	В-Е-С
p2T	PMBT4403	PHIL	npn	$V_{CEB}=40 В; I_C=600 мА; P_D=200 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT323, SC70	В-Е-С



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
p2U	PMBTA63	PHIL	dnpn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 5000; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В-Е-С
p2V	PMBTA64	PHIL	dnpn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 10000; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В-Е-С
p2X	PMBTA401	PHIL	npn	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В-Е-С
p2X	PMST4401	PHIL	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	В-Е-С
P3	BZX84C13T	DIODS	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5 \text{ мА}) = 12.4...14.1 \text{ В}; Z_{T1}(I_{Z1} = 5 \text{ мА}) < 30 \text{ Ом}$	SOT523	A-n.c.-K
P3	TP0202T	SIL	pMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 410 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; g_m = 600 \text{ мСм}; R_{DS(on)} > 0.9 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
P3	TP0202T	TEMIC	pMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 410 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; g_m = 600 \text{ мСм}; R_{DS(on)} > 0.9 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
p30	PDTCl14YU	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; 10 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23, SC70	В-Е-С
p31	PDTA143XT	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; 4.7 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	В-Е-С
p32	PDTCl143XT	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; 4.7 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	В-Е-С
P32	SOS400	SGS	npnp	$V_{CE0} = 130 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40...180; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В-Е-С
P33	SOS401	SGS	npnp	$V_{CE0} = 160 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 60...240; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В-Е-С
P38	SST4338	SIL	nFET	$V_{DS} = 50 \text{ В}; P_D = 300 \text{ мВт}; I_{DSS} < 0.6 \text{ мА}; g_m > 0.6 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
P39	SO692	SGS	npn	$V_{CE0} = 300 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 310 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В-Е-С
P39	SST4339	SIL	nFET	$V_{DS} = 50 \text{ В}; P_D = 300 \text{ мВт}; I_{DSS} < 0.8 \text{ мА}; g_m > 1.5 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
P3W	MMBF2202PT1	MOT	pMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 300 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; R_{DS(on)} = 3.5 \text{ Ом}$	SOT23, SC70	G-S-D
P4	BFR92R	PHIL	npn	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 280 \text{ мВт}; h_{FE1} = 40...200; f_T = 5000 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	C-B-E
P4	BZX84C15T	DIODS	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5 \text{ мА}) = 13.8...15.6 \text{ В}; Z_{T1}(I_{Z1} = 5 \text{ мА}) < 30 \text{ Ом}$	SOT523	A-n.c.-K
P4	SST204	SIL	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; P_D = 350 \text{ мВт}; I_{DSS} = 0.2...3 \text{ мА}; g_m > 0.5 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
P40	SST4340	SIL	nFET	$V_{DS} = 50 \text{ В}; P_D = 300 \text{ мВт}; I_{DSS} < 1.3 \text{ мА}; g_m > 9 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
P41	SST4341	SIL	nFET	$V_{DS} = 50 \text{ В}; P_D = 300 \text{ мВт}; I_{DSS} < 2 \text{ мА}; g_m > 1.5 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
p46	PDTA143XU	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; 4.7 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT23, SC70	В-Е-С
p47	PDTA143ZU	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23, SC70	В-Е-С
p4F	PMBD353	PHIL	shd-2	$V_B < 4 \text{ В}; I_C < 30 \text{ мА}; V_{Z1}(I_{Z1} = 10 \text{ мА}) < 600 \text{ мВ}; C_D < 1 \text{ пФ}$	SOT23, SOD23	K1-A2-A1, K2
P5	BFR92AR	PHIL	npn	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; I_C = 25 \text{ мА}; P_D = 273 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T = 4500 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	C-B-E
P5	BZX84C16T	DIODS	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5 \text{ мА}) = 15.3...17.1 \text{ В}; Z_{T1}(I_{Z1} = 5 \text{ мА}) < 40 \text{ Ом}$	SOT523	A-n.c.-K
P5	FMMT2369A	ZETEX	pMOS	$V_{DS} = 40 \text{ В}; I_D = 200 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40...120$	SOT23, SOD23	В-Е-С
p53	PDTCl143XU	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; 4.7 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT23, SC70	В-Е-С
p54	PDTCl143ZU	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23, SC70	В-Е-С
p55	PDTA114YU	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; 10 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23, SC70	В-Е-С
P57	SST5457	SIL	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; P_D = 310 \text{ мВт}; I_{DSS} = 1...5 \text{ мА}; g_m < 1 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
P58	SST5458	SIL	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; P_D = 310 \text{ мВт}; I_{DSS} = 1...5 \text{ мА}; g_m < 1.5 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
P59	SST5459	SIL	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; P_D = 350 \text{ мВт}; I_{DSS} = 4...16 \text{ мА}; g_m < 2 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
p5A	PMBD6050	PHIL	fd	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 215 \text{ мА}; V_{Z1}(I_{Z1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_B < 100 \text{ нА}; C_D = 1.5 \text{ пФ}; I_{SS} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p5B	PMBD6100	PHIL	fd-2	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 215 \text{ мА}; V_{Z1}(I_{Z1} = 100 \text{ мА}) < 0.85...1.1 \text{ В}; I_B < 100 \text{ нА}; C_D < 1.5 \text{ пФ}; I_{SS} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
p5C	PMBD7000	PHIL	fd-2	$V_B < 100 \text{ В}; I_C < 215 \text{ мА}; V_{Z1}(I_{Z1} = 100 \text{ мА}) < 0.75...1.25 \text{ В}; I_B < 500 \text{ нА}; C_D < 1.5 \text{ пФ}; I_{SS} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
p5D	PMBD914	PHIL	fd	$V_B < 70 \text{ В}; I_C < 215 \text{ мА}; V_{Z1}(I_{Z1} = 150 \text{ мА}) < 1.25 \text{ В}; I_{обр} < 1 \text{ мкА}; C_D < 1.5 \text{ пФ}; I_{SS} < 4 \text{ нС}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p5G	PMBD352	PHIL	shd-2	$V_B < 4 \text{ В}; I_C < 30 \text{ мА}; V_{Z1}(I_{Z1} = 10 \text{ мА}) < 600 \text{ мВ}; C_D < 1 \text{ пФ}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
P6	BZX84C18T	DIODS	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 5 \text{ мА}) = 16.8...19.1 \text{ В}; Z_{T1}(I_{Z1} = 5 \text{ мА}) < 45 \text{ Ом}$	SOT523	A-n.c.-K
P63	SST5463	SIL	pFET	$V_{DS} = 60 \text{ В}; P_D = 310 \text{ мВт}; I_{DSS} > 5 \text{ мА}; g_m = 1...4 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
P64	SST5464	SIL	pFET	$V_{DS} = 60 \text{ В}; P_D = 310 \text{ мВт}; I_{DSS} = 2...9 \text{ мА}; g_m < 5 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
P65	SST5465	SIL	pFET	$V_{DS} = 60 \text{ В}; P_D = 310 \text{ мВт}; I_{DSS} = 4...16 \text{ мА}; g_m < 6 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
p6A	PMBF4416	PHIL	nFET	$V_{DS} = 30 \text{ В}; I_{DSS} = 15 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; g_m < 7.5 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	S-D-G
p6B	PMBF5484	PHIL	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; I_{DSS} = 5 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; g_m < 6 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	S-D-G
p6G	PMBF4393	PHIL	nFET	$V_{DS} = 40 \text{ В}; I_{DSS} = 5 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 100 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
p6H	PMBF5486	PHIL	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; I_{DSS} = 15 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; g_m < 8 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	S-D-G
p6J	PMBF4391	PHIL	nFET	$V_{DS} = 40 \text{ В}; I_{DSS} = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
p6K	PMBF4392	PHIL	nFET	$V_{DS} = 40 \text{ В}; I_{DSS} = 25 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 60 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
p6M	PMBF5485	PHIL	nFET	$V_{DS} = 25 \text{ В}; I_{DSS} = 10 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; g_m < 7 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	S-D-G

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
p6S	PMBFJ176	PHIL	pFET	$V_{DS} < 30 \text{ В}; I_{DSS} > 2 \text{ мА}; P_D < 300 \text{ мВт}; R_{\theta DS(om)} < 250 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
p6W	PMBFJ175	PHIL	pFET	$V_{DS} < 30 \text{ В}; I_{DSS} > 7 \text{ мА}; P_D < 300 \text{ мВт}; R_{\theta DS(om)} < 125 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
p6X	PMBFJ174	PHIL	pFET	$V_{DS} < 30 \text{ В}; I_{DSS} > 20 \text{ мА}; P_D < 300 \text{ мВт}; R_{\theta DS(om)} < 85 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
p6Y	PMBFJ177	PHIL	pFET	$V_{DS} < 30 \text{ В}; I_{DSS} > 1.5 \text{ мА}; P_D < 300 \text{ мВт}; R_{\theta DS(om)} < 300 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
P7	BZX84C20T	DIODS	dz	$V_{ZT}(I_Z = 5 \text{ мА}) = 18.8...21.2 \text{ В}; Z_{T1}(I_Z = 5 \text{ мА}) < 55 \text{ Ом}$	SOT523	A1-K2-K1, A2
p7Y	PDTB123YT	PHIL	Dnpnp	$V_{CES} < 50 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 250 \text{ мВт}; h_{FE} > 70; 2.2 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	B-E-C
P8	BZX84C22T	DIODS	dz	$V_{ZT}(I_Z = 5 \text{ мА}) = 20.8...23.3 \text{ В}; Z_{T1}(I_Z = 5 \text{ мА}) < 55 \text{ Ом}$	SOT523	A-n.c.-K
P8A	FLLD261	ZETEX	d-2	$V_R < 100 \text{ В}; I_R < 250 \text{ мА}; V_{R1}(I_R = 200 \text{ мА}) < 1.4 \text{ В}; I_R < 5 \text{ мкА}; C_D < 4 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
P8A	FLLD261	FAIR	d-2	$V_R < 100 \text{ В}; I_R < 250 \text{ мА}; V_{R1}(I_R = 200 \text{ мА}) < 1.4 \text{ В}; I_R < 5 \text{ мкА}; C_D < 4 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
p8A	PMBZ5226B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 3.3 \text{ В}; I_V(V_R = 1.0 \text{ В}) < 25 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 1600 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8B	PMBZ5227B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 3.6 \text{ В}; I_V(V_R = 1.0 \text{ В}) < 15 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 1700 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8C	PMBZ5228B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 3.9 \text{ В}; I_V(V_R = 1.0 \text{ В}) < 10 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 1900 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8D	PMBZ5229B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 4.3 \text{ В}; I_V(V_R = 1.0 \text{ В}) < 5 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 2000 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8E	PMBZ5230B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 4.7 \text{ В}; I_V(V_R = 1.0 \text{ В}) < 5 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 2000 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8F	PMBZ5231B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 5.1 \text{ В}; I_V(V_R = 2.0 \text{ В}) < 5 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 2000 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8G	PMBZ5232B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 5.6 \text{ В}; I_V(V_R = 3.0 \text{ В}) < 5 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 1600 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8H	PMBZ5233B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 6.0 \text{ В}; I_V(V_R = 3.5 \text{ В}) < 5 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 1600 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8J	PMBZ5234B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 6.2 \text{ В}; I_V(V_R = 4.0 \text{ В}) < 5 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 1000 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8K	PMBZ5235B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 6.8 \text{ В}; I_V(V_R = 5.0 \text{ В}) < 3 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 750 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8L	PMBZ5236B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 7.5 \text{ В}; I_V(V_R = 6.0 \text{ В}) < 3 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 500 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8M	PMBZ5237B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 8.2 \text{ В}; I_V(V_R = 6.5 \text{ В}) < 3 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 500 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8N	PMBZ5238B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 8.7 \text{ В}; I_V(V_R = 6.5 \text{ В}) < 3 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 600 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8P	PMBZ5239B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 9.1 \text{ В}; I_V(V_R = 7.0 \text{ В}) < 3 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 600 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8Q	PMBZ5240B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 10 \text{ В}; I_V(V_R = 8.0 \text{ В}) < 3 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 600 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8R	PMBZ5241B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 11 \text{ В}; I_V(V_R = 8.4 \text{ В}) < 2 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 600 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8S	PMBZ5242B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 20 \text{ мА}) = 12 \text{ В}; I_V(V_R = 9.1 \text{ В}) < 1 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 20 \text{ мА}) < 600 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8T	PMBZ5243B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 9.5 \text{ мА}) = 13 \text{ В}; I_V(V_R = 9.9 \text{ В}) < 0.5 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 9.5 \text{ мА}) < 600 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8U	PMBZ5244B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 9.0 \text{ мА}) = 14 \text{ В}; I_V(V_R = 10 \text{ В}) < 0.1 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 9.0 \text{ мА}) < 600 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8V	PMBZ5245B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 8.5 \text{ мА}) = 15 \text{ В}; I_V(V_R = 11 \text{ В}) < 0.1 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 8.5 \text{ мА}) < 600 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8W	PMBZ5246B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 7.8 \text{ мА}) = 16 \text{ В}; I_V(V_R = 12 \text{ В}) < 0.1 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 7.8 \text{ мА}) < 600 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8X	PMBZ5247B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 7.4 \text{ мА}) = 17 \text{ В}; I_V(V_R = 13 \text{ В}) < 0.1 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 7.4 \text{ мА}) < 600 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8Y	PMBZ5248B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 7.0 \text{ мА}) = 18 \text{ В}; I_V(V_R = 14 \text{ В}) < 0.1 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 7.0 \text{ мА}) < 600 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
p8Z	PMBZ5249B	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_Z = 6.6 \text{ мА}) = 19 \text{ В}; I_V(V_R = 14 \text{ В}) < 0.1 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_Z = 6.6 \text{ мА}) < 600 \text{ Ом}; I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
P9	BCX70KR	ZETEX	npn	$V_{CES} < 45 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 380...630; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3
P9	BCX70KR	PHIL	nnp	V_{CBO} : 45 В; I_C : 200 мА; P_D : 330 мВт; h_{FE1} : 380...630; f_T : >250 МГц	SOT23, SOD23	C·B·E
P9	BZX84C24T	DIODS	dz	$V_{D1}(I_T=5 \text{ mA})$: 22.8...25.6 В; $Z_{T1}(I_T=5 \text{ mA})$: <70 Ом	SOT523	A·n.c.·K
P9	DAP222	ON	di-2	V_A : 80 В; I_C : 300 мА; P_D : <150 мВт; $V_{CE}(I_C=100 \text{ mA})$: <1.2 В; $t_{95\%}$: <4 нс	SOT416, SC75A	K1·K2·A1, A2
p9A	PLVA650A	PHIL	dz	$V_{D1}(I_T=250 \text{ mA})$: 4.8...5.2 В; $I_{D1}(V_{D1}=0.8 \cdot V_A)$: <20 мА; $Z_{T1}(I_T=250 \text{ mA})$: <700 Ом; I_{B1} : 250 мА	SOT23, SOD23	A·n.c.·K
p9B	PLVA653A	PHIL	dz	$V_{D1}(I_T=250 \text{ mA})$: 5.1...5.5 В; $I_{D1}(V_{D1}=0.8 \cdot V_A)$: <5 мА; $Z_{T1}(I_T=250 \text{ mA})$: <250 Ом; I_{B1} : 250 мА	SOT23, SOD23	A·n.c.·K
p9C	PLVA656A	PHIL	dz	$V_{D1}(I_T=250 \text{ mA})$: 5.4...5.8 В; $I_{D1}(V_{D1}=0.8 \cdot V_A)$: <1 мА; $Z_{T1}(I_T=250 \text{ mA})$: <100 Ом; I_{B1} : 250 мА	SOT23, SOD23	A·n.c.·K
p9D	PLVA659A	PHIL	dz	$V_{D1}(I_T=250 \text{ mA})$: 5.7...6.1 В; $I_{D1}(V_{D1}=0.8 \cdot V_A)$: <500 нА; $Z_{T1}(I_T=250 \text{ mA})$: <100 Ом; I_{B1} : 250 мА	SOT23, SOD23	A·n.c.·K
p9E	PLVA662A	PHIL	dz	$V_{D1}(I_T=250 \text{ mA})$: 6.0...6.4 В; $I_{D1}(V_{D1}=0.8 \cdot V_A)$: <100 нА; $Z_{T1}(I_T=250 \text{ mA})$: <100 Ом; I_{B1} : 250 мА	SOT23, SOD23	A·n.c.·K
p9F	PLVA665A	PHIL	dz	$V_{D1}(I_T=250 \text{ mA})$: 6.3...6.7 В; $I_{D1}(V_{D1}=0.8 \cdot V_A)$: <50 нА; $Z_{T1}(I_T=250 \text{ mA})$: <100 Ом; I_{B1} : 250 мА	SOT23, SOD23	A·n.c.·K
p9G	PLVA668A	PHIL	dz	$V_{D1}(I_T=250 \text{ mA})$: 6.6...7.0 В; $I_{D1}(V_{D1}=0.8 \cdot V_A)$: <10 нА; $Z_{T1}(I_T=250 \text{ mA})$: <100 Ом; I_{B1} : 250 мА	SOT23, SOD23	A·n.c.·K
p9J	PLVA2650A	PHIL	dz-2	$V_{D1}(I_T=250 \text{ mA})$: 4.8...5.2 В; $I_{D1}(V_{D1}=0.8 \cdot V_A)$: <20 мА; $Z_{T1}(I_T=250 \text{ mA})$: <700 Ом; I_{B1} : 250 мА	SOT23, SOD23	K1·K2·A1, A2
p9K	PLVA2653A	PHIL	dz-2	$V_{D1}(I_T=250 \text{ mA})$: 5.1...5.5 В; $I_{D1}(V_{D1}=0.8 \cdot V_A)$: <5 мА; $Z_{T1}(I_T=250 \text{ mA})$: <250 Ом; I_{B1} : 250 мА	SOT23, SOD23	K1·K2·A1, A2
p9L	PLVA2656A	PHIL	dz-2	$V_{D1}(I_T=250 \text{ mA})$: 5.4...5.8 В; $I_{D1}(V_{D1}=0.8 \cdot V_A)$: <1 мА; $Z_{T1}(I_T=250 \text{ mA})$: <100 Ом; I_{B1} : 250 мА	SOT23, SOD23	K1·K2·A1, A2
p9M	PLVA2659A	PHIL	dz-2	$V_{D1}(I_T=250 \text{ mA})$: 5.7...6.1 В; $I_{D1}(V_{D1}=0.8 \cdot V_A)$: <500 нА; $Z_{T1}(I_T=250 \text{ mA})$: <100 Ом; I_{B1} : 250 мА	SOT23, SOD23	K1·K2·A1, A2
p9N	PLVA2662A	PHIL	dz-2	$V_{D1}(I_T=250 \text{ mA})$: 6.0...6.4 В; $I_{D1}(V_{D1}=0.8 \cdot V_A)$: <100 нА; $Z_{T1}(I_T=250 \text{ mA})$: <100 Ом; I_{B1} : 250 мА	SOT23, SOD23	K1·K2·A1, A2
p9O	PLVA2665A	PHIL	dz-2	$V_{D1}(I_T=250 \text{ mA})$: 6.3...6.7 В; $I_{D1}(V_{D1}=0.8 \cdot V_A)$: <50 нА; $Z_{T1}(I_T=250 \text{ mA})$: <100 Ом; I_{B1} : 250 мА	SOT23, SOD23	K1·K2·A1, A2
p9P	PLVA2668A	PHIL	dz-2	$V_{D1}(I_T=250 \text{ mA})$: 6.6...7.0 В; $I_{D1}(V_{D1}=0.8 \cdot V_A)$: <10 нА; $Z_{T1}(I_T=250 \text{ mA})$: <100 Ом; I_{B1} : 250 мА	SOT23, SOD23	K1·K2·A1, A2
PA	2SC4666	TOSH	nnp	V_{CBO} : 50 В; I_C : 150 мА; P_D : 100 мВт; h_{FE1} : >600...1800; f_T : 250 МГц	SOT323, SC70	B·E·C
PA	BA885	INF	pin	V_A : 50 В; I_C : 50 мА; $V_{F1}(I_C=50 \text{ mA})$: <1.1 В; I_B : <0.05 мА; C_D : <0.4 нФ	SOT23, SOD23	A·n.c.·K
pA2	PMBD2836	PHIL	fd-2	V_A : 75 В; I_C : <215 мА; $V_{CE}(I_C=150 \text{ mA})$: <1.25 В; I_B : <100 нА; C_D : <2.5 нФ; $t_{95\%}$: <4 нс	SOT23, SOD23	K1·K2·A1, A2
pA3	PMBD2835	PHIL	fd-2	V_A : 35 В; I_C : <215 мА; $V_{CE}(I_C=150 \text{ mA})$: <1.25 В; I_B : <100 нА; C_D : <2.5 нФ; $t_{95\%}$: <4 нс	SOT23, SOD23	K1·K2·A1, A2
pA5	PMBD2837	PHIL	fd-2	V_A : 30 В; I_C : <215 мА; $V_{CE}(I_C=150 \text{ mA})$: <1.25 В; I_B : <100 нА; C_D : <2.5 нФ; $t_{95\%}$: <4 нс	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
pA6	PMBD2838	PHIL	fd-2	V_A : 50 В; I_C : <215 мА; $V_{CE}(I_C=150 \text{ mA})$: <1.25 В; I_B : <100 нА; C_D : <2.5 нФ; $t_{95\%}$: <4 нс	SOT23, SOD23	A1·A2·K1, K2
PB	2SC4666	TOSH	nnp	V_{CBO} : 50 В; I_C : 150 мА; P_D : 100 мВт; h_{FE1} : >1200...3600; f_T : 250 МГц	SOT323, SC70	B·E·C
PC	BA886	INF	pin	V_A : 50 В; I_C : 50 мА; $V_{F1}(I_C=50 \text{ mA})$: <1.15 В; I_B : <0.05 мА; C_D : <0.2 нФ	SOT23, SOD23	A·n.c.·K
PC	MGSF1P02L	ON	pMos	V_{DS} : 20 В; I_D : 750 мА; P_D : 400 мВт; $R_{DS(on)}$: <0.5 Ом	SOT23, SOD23	G·S·D
PD	2SA1171D	REN	npnp	V_{CBO} : 90 В; I_C : 50 мА; P_D : 150 мВт; h_{FE1} : 250...500	SOT23, SOD23	B·E·C
PD	BSS84L	MOT	pMos	V_{DS} : 50 В; I_D : 130 мА; P_D : 360 мВт; g_m : 50 мСм; $R_{DS(on)}$: 10 Ом	SOT23, SOD23	G·S·D
PDs	BA887	INF	pin	V_A : 50 В; I_C : 100 мА; I_B : <0.02 мА; C_D : <0.27 нФ	SOT23, SOD23	A·n.c.·K
PE	2SA1171E	REN	npnp	V_{CBO} : 90 В; I_C : 50 мА; P_D : 150 мВт; h_{FE1} : 400...800	SOT23, SOD23	B·E·C
pG1	PMBT5551	PHIL	npn	V_{CBO} : 180 В; I_C : 600 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : 80...250; f_T : 100...300	SOT23, SOD23	B·E·C
PH	KRA307	KEC	npn	V_{CBO} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 100 мВт; R_T/R_2 : 10/47 кОм	SOT323, SC70	B·E·C
PH2	SST4302	SIL	nFET	V_{DS} : 30 В; P_D : 300 мВт; I_{DSS} : >5 мА; g_m : 1 мСм	SOT23, SOD23	D·S·G
PH3	SST4303	SIL	nFET	V_{DS} : 30 В; P_D : 300 мВт; I_{DSS} : >10 мА; g_m : 2 мСм	SOT23, SOD23	D·S·G
PH4	SST4304	SIL	nFET	V_{DS} : 30 В; P_D : 300 мВт; I_{DSS} : >15 мА; g_m : 2 мСм	SOT23, SOD23	D·S·G
PI	KRA308	KEC	npn	V_{CBO} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 100 мВт; R_T/R_2 : 22/47 кОм	SOT323, SC70	B·E·C
PIB	2SK1070B	REN	nFET	V_{GS} : >22 В; I_D : 50 мА; P_D : 150 мВт; g_m : >20 мСм; I_{DSS} : 6...14 мА	SOT23, SOD23	S·D·G
PIC	2SK1070C	REN	nFET	V_{GS} : >22 В; I_D : 50 мА; P_D : 150 мВт; g_m : >20 мСм; I_{DSS} : 12...22 мА	SOT23, SOD23	S·D·G

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT525

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
KID	2SK1070D	REN	nFET	$V_{GS} > 22\text{ В}; I_D = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; g_f > 20\text{ мСм}; I_{DSS} = 18...30\text{ мА}$	SOT23,SOD23	S-D-G
PIE	2SK1070E	REN	nFET	$V_{GS} > 22\text{ В}; I_D = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; g_f > 20\text{ мСм}; I_{DSS} = 27...40\text{ мА}$	SOT23,SOD23	S-D-G
PJ	KRA909	KEC	pnп	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; R_{\theta jC}/R_{\theta jA} = 47/22\text{ К/мСм}$	SOT323,SC70	B-E-C
рJ1	BSH101	PHIL	nMOS	$V_{GS} = 60\text{ В}; I_D = 700\text{ мА}; P_D = 500\text{ мВт}; R_{DS(on)} < 0.6\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	G-S-D
рJ2	BSH102	PHIL	nMOS	$V_{GS} = 30\text{ В}; I_D = 1\text{ А}$	SOT23,SOD23	G-S-D
рJ3	BSH103	PHIL	nMOS	$V_{GS} = 30\text{ В}; I_D = 850\text{ мА}; P_D = 500\text{ мВт}; R_{DS(on)} < 0.5\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	G-S-D
PMs	BAR66	INF	pin-2	$V_R < 150\text{ В}; I_C < 200\text{ мА}; V_{F(I_C = 50\text{ мА})} < 1.1\text{ В}; C_D < 0.35\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1-A2
рQ4	PMBS3904	PHIL	pnп	$V_{CE} = 60\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{FE} = 100...300; f_T > 180\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
рQ6	PMBS3906	PHIL	pnп	$V_{CE} = 40\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{FE} = 100...300; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
POs	BAR64	SIEM	pin	$V_R < 200\text{ В}; I_C < 100\text{ мА}; V_{F(I_C = 50\text{ мА})} < 1.1\text{ В}; C_D < 0.35\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
PPs	BAR6404	SIEM	pin-2	$V_R < 200\text{ В}; I_C < 100\text{ мА}; V_{F(I_C = 50\text{ мА})} < 1.1\text{ В}; C_D < 0.35\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1-A2
PPs	BAR64-04	INF	pin-2	$V_R < 150\text{ В}; I_C < 100\text{ мА}; V_{F(I_C = 50\text{ мА})} < 1.1\text{ В}; C_D < 0.35\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1-A2
PPs	BAR64-04W	INF	pin-2	$V_R < 150\text{ В}; I_C < 100\text{ мА}; V_{F(I_C = 50\text{ мА})} < 1.1\text{ В}; C_D < 0.35\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1-K2-K1-A2
PPs	BAR64-04W	INF	pin-2	$V_R < 150\text{ В}; I_C < 100\text{ мА}; V_{F(I_C = 50\text{ мА})} < 1.1\text{ В}; C_D < 0.35\text{ нФ}$	SOT416,SC75A	A1-K2-K1-A2
PRs	BAR6405	SIEM	pin-2	$V_R < 200\text{ В}; I_C < 100\text{ мА}; V_{F(I_C = 50\text{ мА})} < 1.1\text{ В}; C_D < 0.35\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
PRs	BAR64-05	INF	pin-2	$V_R < 150\text{ В}; I_C < 100\text{ мА}; V_{F(I_C = 50\text{ мА})} < 1.1\text{ В}; C_D < 0.35\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
PRs	BAR64-05W	INF	pin-2	$V_R < 150\text{ В}; I_C < 100\text{ мА}; V_{F(I_C = 50\text{ мА})} < 1.1\text{ В}; C_D < 0.35\text{ нФ}$	SOT323,SC70	A1-A2-K1,K2
PS	TP0101TS	SIL	рMOS	$V_{GS} = 20\text{ В}; I_D = 1000\text{ мА}; P_D = 1000\text{ мВт}; g_f = 1300\text{ мСм}; R_{DS(on)} = 0.65\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	G-S-D
PSs	BAR6406	SIEM	pin-2	$V_R < 200\text{ В}; I_C < 100\text{ мА}; V_{F(I_C = 50\text{ мА})} < 1.1\text{ В}; C_D < 0.35\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
PSs	BAR64-06	INF	pin-2	$V_R < 150\text{ В}; I_C < 100\text{ мА}; V_{F(I_C = 50\text{ мА})} < 1.1\text{ В}; C_D < 0.35\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
PSs	BAR64-06W	INF	pin-2	$V_R < 150\text{ В}; I_C < 100\text{ мА}; V_{F(I_C = 50\text{ мА})} < 1.1\text{ В}; C_D < 0.35\text{ нФ}$	SOT323,SC70	K1-K2-A1,A2
PV	1SV294	SANYO	pin	$V_R > 50\text{ В}; I_C < 50\text{ мА}; V_{F(I_C = 50\text{ мА})} = 0.92...0.97\text{ В}; I_C < 0.1\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
рV3	BAT54A	PHIL	shd-2	$V_R < 50\text{ В}; I_C < 200\text{ мА}; V_{F(I_C = 30\text{ мА})} < 500\text{ мВ}; C_D < 10\text{ пФ}; I_{TSM} < 5\text{ нС}$	SOT23,SOD23	K1-K2-A1,A2
рV4	BAT54S	PHIL	shd-2	$V_R < 30\text{ В}; I_C < 200\text{ мА}; V_{F(I_C = 30\text{ мА})} < 500\text{ мВ}; C_D < 10\text{ пФ}; I_{TSM} < 5\text{ нС}$	SOT23,SOD23	A1-K2-K1,A2
рW1	BAT54C	PHIL	shd-2	$V_R < 30\text{ В}; I_C < 200\text{ мА}; V_{F(I_C = 30\text{ мА})} < 500\text{ мВ}; C_D < 10\text{ пФ}; I_{TSM} < 5\text{ нС}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
Q0	MCP100T-475/IT	MCHIP	mrc	$V_{TR} = 4.625\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{DD} < 60\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	RST-VDD-VSS
Q2	MMBC1321Q2	MOT	npn	$V_{CE} = 30\text{ В}; I_C = 10\text{ мА}; h_{FE} = 40...80$	SOT23,SOD23	B-E-C
Q3	MMBC1321Q3	MOT	npn	$V_{CE} = 30\text{ В}; I_C = 10\text{ мА}; h_{FE} = 60...120$	SOT23,SOD23	B-E-C
Q4	MMBC1321Q4	MOT	npn	$V_{CE} = 30\text{ В}; I_C = 10\text{ мА}; h_{FE} = 90...180$	SOT23,SOD23	B-E-C
Q5	MMBC1321Q5	MOT	npn	$V_{CE} = 30\text{ В}; I_C = 10\text{ мА}; h_{FE} = 135...270$	SOT23,SOD23	B-E-C
QA	RN1421	TOSH	Dnnp	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_C = 800\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T > 250\text{ МГц}; R_{\theta jC}/R_{\theta jA} = 1/1\text{ К/мСм}$	SOT346,SC59	B-E-C
QAA	BC846AF	AUK	npn	$V_{CE} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{FE} = 110...220; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT490,SC89	B-E-C
QAB	BC846BF	AUK	npn	$V_{CE} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{FE} = 200...450; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT490,SC89	B-E-C
QAC	BC846CF	AUK	npn	$V_{CE} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{FE} = 420...800; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT490,SC89	B-E-C
QB	RN1422	TOSH	Dnnp	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_C = 800\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T > 250\text{ МГц}; R_{\theta jC}/R_{\theta jA} = 2.2/2.2\text{ К/мСм}$	SOT346,SC59	B-E-C
QC	RN1423	TOSH	Dnnp	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_C = 800\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T > 250\text{ МГц}; R_{\theta jC}/R_{\theta jA} = 4.7/4.7\text{ К/мСм}$	SOT346,SC59	B-E-C
QD	RN1424	TOSH	Dnnp	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_C = 800\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T > 250\text{ МГц}; R_{\theta jC}/R_{\theta jA} = 10/10\text{ К/мСм}$	SOT346,SC59	B-E-C
QE	RN1425	TOSH	Dnnp	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_C = 800\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T > 250\text{ МГц}; R_{\theta jC}/R_{\theta jA} = 0.47/10\text{ К/мСм}$	SOT346,SC59	B-E-C
QF	RN1426	TOSH	Dnnp	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_C = 800\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T > 250\text{ МГц}; R_{\theta jC}/R_{\theta jA} = 1/10\text{ К/мСм}$	SOT346,SC59	B-E-C
QG	RN1427	TOSH	Dnnp	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_C = 800\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T > 250\text{ МГц}; R_{\theta jC}/R_{\theta jA} = 2.2/10\text{ К/мСм}$	SOT346,SC59	B-E-C
QI	2SC4196	REN	npn	$V_{CE} = 25\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{FE} = 50...180; f_T > 1.8\text{ ГГц}$	SOT346,SC59	B-E-C
QJ	2SC4261	REN	npn	$V_{CE} = 25\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; h_{FE} = 50...180; f_T > 1.8\text{ ГГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
QJ	MCP100T-270/IT	MCHIP	mrc	$V_{TR} = 2.625\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{DD} < 60\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	RST-VDD-VSS
QK	MCP100T-300/IT	MCHIP	mrc	$V_{TR} = 2.925\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{DD} < 60\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	RST-VDD-VSS
QL	MCP100T-315/IT	MCHIP	mrc	$V_{TR} = 3.075\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{DD} < 60\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	RST-VDD-VSS
QM	MCP100T-450/IT	MCHIP	mrc	$V_{TR} = 4.375\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{DD} < 60\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	RST-VDD-VSS
QN	MCP100T-460/IT	MCHIP	mrc	$V_{TR} = 4.475\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{DD} < 60\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	RST-VDD-VSS
QO	KTC4080	KEC	npn	$V_{CE} = 40\text{ В}; I_C = 20\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; h_{FE} = 70...140; f_T > 550\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
QP	MCP100T-485/IT	MCHIP	mrc	$V_{TR} = 4.725\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{DD} < 60\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	RST-VDD-VSS
QR	KTC4080	KEC	npn	$V_{CE} = 40\text{ В}; I_C = 20\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; h_{FE} = 40...80; f_T > 550\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
QY	KTC4080	KEC	npn	$V_{CE} = 40\text{ В}; I_C = 20\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; h_{FE} = 100...200; f_T > 550\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
RO	MCP101T-475/IT	MCHIP	mrc	$V_{TR} = 4.625\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{DD} < 60\text{ мкА}$	SOT23,SOD23	RST-VDD-VSS



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3
R01	KSR1101	SAMS	Dnnp	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 20; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R02	KSR1102	SAMS	Dnnp	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 30; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R03	KSR1103	SAMS	Dnnp	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 56; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R04	KSR11104	SAMS	Dnnp	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 68; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R05	KSR11105	SAMS	Dnnp	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 30; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R06	KSR11106	SAMS	Dnnp	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 68; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R07	KSR11107	SAMS	Dnnp	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 68; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R08	KSR11108	SAMS	Dnnp	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 56; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R09	KSR11109	SAMS	Dnnp	$V_{CBO} = 40 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 100...600; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1	BF93	SGS	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 50...200; f_T = 5500 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1	BZX84C4V7T	DIODS	dz	$V_{ZF}(I_Z = 5 мА) = 4...5.0 В; Z_T(I_Z = 5 мА) = 80 Ом$	SOT523	A•n.c. •K
R1	HSMS-8101	HP	shd	$V_{BR} > 4 В; V_{F(I_F = 1 мА)} < 0.35 В; C_D < 0.26 нФ; R_D = 14 Ом$	SOT23, SOD23	n.c. •A •K
R1	TN20110	SIL	nMOS	$V_{DS} = 200 В; I_D = 120 мА; P_D = 360 мВт; g_{fs} = 300 мСм; P_{D(ON)} = 9.5 Ом$	SOT23, SOD23	G•S•D
R10	KSR11101	SAMS	npn	$V_{CBO} = 40 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 100...600; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R11	KSR11111	SAMS	npn	$V_{CBO} = 40 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 100...600; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R12	KSR11112	SAMS	npn	$V_{CBO} = 40 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 100...600; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R13	ZSC4885	NEC	npn	$V_{CBO} = 25 В; I_C = 50 мА; P_D = 120 мВт; h_{FE} > 60...150; f_T > 2.5 ГГц$	SOT323, SC70	В•Е•С
R13	KSR11113	SAMS	Dnnp	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 56; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R14	KSR11114	SAMS	Dnnp	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 68; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1A	MMBT3904	VISH	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 100...300; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1A	MMST3904	ROHM	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 200 мА; h_{FE} > 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT346, SC59	В•Е•С
R1A	SST3904	ROHM	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 200 мА; h_{FE} > 100...300; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1A	UMT3904	ROHM	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 200 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 100; f_T > 300 МГц$	SOT323, SC70	В•Е•С
R1B	MMST2222	ROHM	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 600 мА; h_{FE} > 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT346, SC59	В•Е•С
R1B	SST2222	ROHM	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 600 мА; h_{FE} > 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1C	MMST1130	ROHM	npn	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 200 мА; h_{FE} > 120...360$	SOT346, SC59	В•Е•С
R1C	MMSTA20	ROHM	npn	$V_{CBO} = 40 В; I_C = 200 мА; h_{FE} > 120; f_T > 125 МГц$	SOT346, SC59	В•Е•С
R1C	SST1130	ROHM	npn	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 200 мА; h_{FE} > 120...360$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1C	SSTA20	ROHM	npn	$V_{CBO} = 40 В; I_C = 200 мА; h_{FE} > 120; f_T > 125 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1G	MMBTA06	VISH	npn	$V_{CBO} = 80 В; I_C = 300 мА; P_D = 350 мВт; h_{FE} > 50; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1G	MMSTA06	ROHM	npn	$V_{CBO} = 80 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 100; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1G	MMSTA06	ROHM	npn	$V_{CBO} = 80 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 100; f_T > 100 МГц$	SOT346, SC59	В•Е•С
R1G	SSTA06	ROHM	npn	$V_{CBO} = 80 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 100; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1H	MMBTA05	VISH	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 30 мА; P_D = 350 мВт; h_{FE} > 50; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1H	SSTA05	ROHM	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 100; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1J	SST6427	ROHM	npn	$V_{CBO} = 40 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 20000...200000$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1K	MMST6428	ROHM	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 200 мА; h_{FE} > 250...650; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1K	MMST6428	ROHM	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 200 мА; h_{FE} > 250...650; f_T > 100 МГц$	SOT346, SC59	В•Е•С
R1K	SST6428	ROHM	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 200 мА; h_{FE} > 250...650; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1M	MMBTA13	VISH	dnnp	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 300 мА; P_D = 350 мВт; h_{FE} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1M	MMSTA13	ROHM	dnnp	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1M	MMSTA13	ROHM	dnnp	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT346, SC59	В•Е•С
R1M	SSTA13	ROHM	dnnp	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1N	MMBTA14	VISH	dnnp	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 300 мА; P_D = 350 мВт; h_{FE} > 20000; f_T > 125 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1N	MMSTA14	ROHM	dnnp	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 20000; f_T > 125 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1N	MMSTA14	ROHM	dnnp	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 20000; f_T > 125 МГц$	SOT346, SC59	В•Е•С
R1N	SSTA14	ROHM	dnnp	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 20000; f_T > 125 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1O	MMST5088	ROHM	npn	$V_{CBO} = 35 В; I_C = 200 мА; h_{FE} > 300...900; f_T > 50 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1O	MMST5088	ROHM	npn	$V_{CBO} = 35 В; I_C = 200 мА; h_{FE} > 300...900; f_T > 50 МГц$	SOT346, SC59	В•Е•С
R1P	MMBT2222A	VISH	npn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 800 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
R1P	MMST2222A	ROHM	npn	$V_{CBO} = 75 В; I_C = 600 мА; h_{FE} > 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT346, SC59	В•Е•С
R1P	SST2222A	ROHM	npn	$V_{CBO} = 75 В; I_C = 600 мА; h_{FE} > 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
R1P	UMT2222A	ROHM	npn	$V_{CE0} = 75 В; I_C = 800 мА; P_D = 500 мВт; h_{FE} > 30$	SOT323, SC70	B-E-C
R1Q	SST5088	ROHM	npn	$V_{CE0} = 35 В; I_C = 200 мА; h_{FE} = 300...900; f_T > 50 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R1R	MMST5089	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 200 мА; h_{FE} = 400...1200; f_T > 50 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
R1R	SST5089	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 200 мА; h_{FE} = 400...1200; f_T > 50 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2	2SC2351P	NEC	npn	$V_{CE0} = 25 В; I_C = 70 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE} = 40...120; f_T = 4,5 ГГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2	2SC4225	NEC	npn	$V_{CE0} = 25 В; I_C = 70 мА; P_D = 160 мВт; h_{FE} = 40...120; f_T = 4 ГГц$	SOT323, SC70	B-E-C
R2	BFR93A	PHIL	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} = 50...200; f_T = 5500 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2	BFR93ALT1	MOT	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} = 50...200; f_T = 5500 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2	BZX84CSV1T	DIODS	dz	$V_Z(I_{ZT} = 5 мА) = 4,8...5,4 В; Z_T(I_{ZT} = 5 мА) < 60 Ом$	SOT523	A-n.c.-K
R23	2SC3356Q	NEC	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} = 50...100; f_T = 7 ГГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R23	2SC4226	NEC	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE} = 40...80; f_T > 3 ГГц$	SOT323, SC70	B-E-C
R24	2SC3356R	NEC	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} = 80...160; f_T = 7 ГГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R24	2SC4226	NEC	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE} = 70...140; f_T > 3 ГГц$	SOT323, SC70	B-E-C
R25	2SC3356S	NEC	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} = 125...250; f_T = 7 ГГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R25	2SC4226	NEC	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE} = 125...250; f_T > 3 ГГц$	SOT323, SC70	B-E-C
R2A	ADR380ART	AD	vref	$V_{IN} = 2,4...1,8 В; I_{OUT} = 5 мА; V_{OUT} = 2,048 В$	SOT323, SOD23	VIN-VOUT-GND
R2A	MMBT3906	VISH	pnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2A	MMST3906	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 200 мА; h_{FE} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
R2A	SST3906	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 200 мА; h_{FE} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2A	UMT3906	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 200 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 100; f_T > 250 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
R2B	MMST2907	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 600 мА; h_{FE} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
R2B	SST2907	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 600 мА; h_{FE} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2C	MMSTA70	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 200 мА; h_{FE} = 160...400; f_T > 125 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2C	MMSTA70	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 200 мА; h_{FE} = 160...400; f_T > 125 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
R2F	MMST2907A	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 600 мА; h_{FE} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
R2F	SST2907A	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 600 мА; h_{FE} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2F	UMT2907A	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 100; f_T > 200 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
R2G	MMSTA56	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 100; f_T > 50 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2G	MMSTA56	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 100; f_T > 50 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
R2G	SSTA56	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 100; f_T > 50 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2H	SSTA55	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 500 мА; h_{FE} > 100; f_T > 50 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2K	MMST8598	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 200 мА; h_{FE} = 100...300; f_T > 150 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2K	MMST8598	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 200 мА; h_{FE} = 100...300; f_T > 150 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
R2O	MMST5087	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 200 мА; h_{FE} = 250...800; f_T > 40 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2O	MMST5087	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 200 мА; h_{FE} = 250...800; f_T > 40 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
R2P	MMST5086	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 200 мА; h_{FE} = 150...500; f_T > 40 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2P	MMST5086	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 200 мА; h_{FE} = 150...500; f_T > 40 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
R2P	MMST5086	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 200 мА; h_{FE} = 150...500; f_T > 40 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2Q	SST7157	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 200 мА; h_{FE} > 100$	SOT346, SC59	B-E-C
R2s	BFR93A	SIEM	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} = 50...200; f_T = 5500 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2s	BFR93AW	SIEM	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} = 50...200; f_T = 5500 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
R2T	MMBT4403	VISH	pnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 800 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2T	MMST4403	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 600 мА; h_{FE} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
R2T	SST4403	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 600 мА; h_{FE} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2T	UMT4403	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 600 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} > 100; f_T > 200 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
R2U	MMSTA63	ROHM	dpnp	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 300 мА; h_{FE} > 5000; f_T > 125 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
R2U	SSTA63	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 300 мА; h_{FE} > 5000; f_T > 125 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2V	MMSTA64	ROHM	dpnp	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 300 мА; h_{FE} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2V	MMSTA64	ROHM	dpnp	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 300 мА; h_{FE} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
R2V	SSTA64	ROHM	pnp	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 300 мА; h_{FE} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C
R2X	MMBT4401	VISH	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 800 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT323, SOD23	B-E-C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3
R2X	MMST4401	ROHM	npn	V_{CE0} : 60 В; I_C : 600 мА; h_{21} : 100...300; f_T : > 250 МГц	SOT346, SC59	В+Е+С
R2X	SST4401	ROHM	npn	V_{CE0} : 60 В; I_C : 600 мА; h_{21} : 100...300; f_T : > 250 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R2X	UMT4401	ROHM	npn	V_{CE0} : 60 В; I_C : 600 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : > 100; f_T : > 250 МГц	SOT323, SC70	В+Е+С
R2Z	SST4400	ROHM	npn	V_{CE0} : 60 В; I_C : 600 мА; h_{21} : 50...150; f_T : > 200 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R3	2SC2351Q	NEC	npn	V_{CE0} : 25 В; I_C : 70 мА; P_D : 250 мВт; h_{21} : 100...200; f_T : > 4.5 ГГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R3	2SC4225	NEC	npn	V_{CE0} : 25 В; I_C : 70 мА; P_D : 160 мВт; h_{21} : 100...200; f_T : > 4 ГГц	SOT323, SC70	В+Е+С
R3	BZX84C5V6T	DIODS	dz	$V_{Z}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 5.2...6.0 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: < 40 Ом	SOT523	А+н.с.+К
R30A	REF3012AIDBZ	TI	vref	V_{IN} : 1.8...5.5 В; I_{OUT} : 25 мА; V_{OUT} : 1.25 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
R30B	REF3020AIDBZ	TI	vref	V_{IN} : 1.8...5.5 В; I_{OUT} : 25 мА; V_{OUT} : 2.048 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
R30C	REF3025AIDBZ	TI	vref	V_{IN} : 1.8...5.5 В; I_{OUT} : 25 мА; V_{OUT} : 2.5 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
R30D	REF3033AIDBZ	TI	vref	V_{IN} : 1.8...5.5 В; I_{OUT} : 25 мА; V_{OUT} : 3.3 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
R30E	REF3040AIDBZ	TI	vref	V_{IN} : 1.8...5.5 В; I_{OUT} : 25 мА; V_{OUT} : 4.096 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
R30F	REF3030AIDBZ	TI	vref	V_{IN} : 1.8...5.5 В; I_{OUT} : 25 мА; V_{OUT} : 3.0 В	SOT23, SOD23	IN-OUT-GND
R33	2SC3583Q	NEC	npn	V_{CE0} : 20 В; I_C : 65 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 50...100; f_T : 9 ГГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R33	2SC4227	NEC	npn	V_{CE0} : 20 В; I_C : 65 мА; P_D : 150 мВт; h_{21} : 40...90; f_T : > 4.5 ГГц	SOT323, SC70	В+Е+С
R34	2SC3583R	NEC	npn	V_{CE0} : 20 В; I_C : 65 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 80...160; f_T : 9 ГГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R34	2SC4227	NEC	npn	V_{CE0} : 20 В; I_C : 65 мА; P_D : 150 мВт; h_{21} : 70...150; f_T : > 4.5 ГГц	SOT323, SC70	В+Е+С
R35	2SC3583S	NEC	npn	V_{CE0} : 20 В; I_C : 65 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 125...250; f_T : 9 ГГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R35	2SC4227	NEC	npn	V_{CE0} : 20 В; I_C : 65 мА; P_D : 150 мВт; h_{21} : 110...240; f_T : > 4.5 ГГц	SOT323, SC70	В+Е+С
R3A	ADR381ART	AD	vref	V_{IN} : 2.8...18 В; I_{OUT} : 5 мА; V_{OUT} : 2.5 В	SOT23, SOD23	VIN-VOUT-GND
R3B	MMST918	ROHM	npn	V_{CE0} : 30 В; I_C : 50 мА; h_{21} : > 20...650; f_T : 600 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R3B	SST918	ROHM	npn	V_{CE0} : 30 В; I_C : 50 мА; h_{21} : > 75; f_T : > 600 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R4	BFR93R	TELEF	npn	V_{CE0} : 20 В; I_C : 50 мА; P_D : 300 мВт; h_{21} : 50...200; f_T : 5500 МГц	SOT323, SC70	С+В+Е
R4	BZX84C6V2T	DIODS	dz	$V_{Z}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 5.8...6.6 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: < 10 Ом	SOT523	А+н.с.+К
R43	2SC3585Q	NEC	npn	V_{CE0} : 20 В; I_C : 35 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 50...100; f_T : 10 ГГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R43	2SC4228	NEC	npn	V_{CE0} : 20 В; I_C : 35 мА; P_D : 150 мВт; h_{21} : 50...100; f_T : > 5.5 ГГц	SOT323, SC70	В+Е+С
R44	2SC3585R	NEC	npn	V_{CE0} : 20 В; I_C : 35 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 80...160; f_T : 10 ГГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R44	2SC4228	NEC	npn	V_{CE0} : 20 В; I_C : 35 мА; P_D : 150 мВт; h_{21} : 80...160; f_T : > 5.5 ГГц	SOT323, SC70	В+Е+С
R45	2SC3585S	NEC	npn	V_{CE0} : 20 В; I_C : 35 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 125...250; f_T : 10 ГГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R45	2SC4228	NEC	npn	V_{CE0} : 20 В; I_C : 35 мА; P_D : 150 мВт; h_{21} : 125...250; f_T : > 5.5 ГГц	SOT323, SC70	В+Е+С
R5	BFR93AR	SGS	npn	V_{CE0} : 20 В; I_C : 50 мА; P_D : 300 мВт; h_{21} : 50...200; f_T : 5500 МГц	SOT23, SOD23	С+В+Е
R5	BZX84C6V8T	DIODS	dz	$V_{Z}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 6.4...7.2 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: < 15 Ом	SOT523	А+н.с.+К
R51	KSR2101	SAMS	Dpnp	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 20; f_T : > 250 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R52	KSR2102	SAMS	Dpnp	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 30; f_T : > 250 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R53	KSR2103	SAMS	Dpnp	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 56; f_T : > 250 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R54	KSR2104	SAMS	Dpnp	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 68; f_T : > 250 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R55	KSR2105	SAMS	Dpnp	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 30; f_T : > 250 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R56	KSR2106	SAMS	Dpnp	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 68; f_T : > 250 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R57	KSR2107	SAMS	Dpnp	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 68; f_T : > 250 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R58	KSR2108	SAMS	Dpnp	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 56; f_T : > 250 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R59	KSR2109	SAMS	pnp	V_{CE0} : 40 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 100...600; f_T : > 250 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R6	BZX84C7V5T	DIODS	dz	$V_{Z}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 7.0...7.9 В; $Z_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: < 15 Ом	SOT523	А+н.с.+К
R60	KSR2110	SAMS	pnp	V_{CE0} : 40 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 100...600; f_T : > 250 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R61	KSR2111	SAMS	pnp	V_{CE0} : 40 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 100...600; f_T : > 250 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R62	2SC3663	NEC	npn	V_{CE0} : 15 В; I_C : 5 мА; P_D : 50 мВт; h_{21} : 50...250; f_T : 4 ГГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R62	KSR2112	SAMS	pnp	V_{CE0} : 40 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 100...600; f_T : > 250 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R63	KSR2113	SAMS	pnp	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 300 мВт; h_{21} : 68; f_T : > 250 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R64	KSR2114	SAMS	pnp	V_{CE0} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 300 мВт; h_{21} : 68; f_T : > 250 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R65	SSTA65	ROHM	npn	V_{CE0} : 30 В; I_C : 300 мА; h_{21} : 50000; f_T : > 100 МГц	SOT23, SOD23	В+Е+С
R67	BFO67R	VIS	npn	V_{CE0} : 20 В; I_C : 50 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : > 65; f_T : 8 ГГц	SOT23, SOD23	Е+В+С
R6A	2SC4187	NEC	npn	V_{CE0} : 15 В; I_C : 5 мА; P_D : 50 мВт; h_{21} : 50...100; f_T : 4 ГГц	SOT323, SC70	В+Е+С

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3
R6B	2SC4187	NEC	npn	$V_{CE0} = 15 В; I_C = 5 мА; P_D = 50 мВт; \eta_{21} = 80...160; f_T = 4 ГГц$	SOT323, SC70	B-E-C
R6C	2SC4187	NEC	npn	$V_{CE0} = 15 В; I_C = 5 мА; P_D = 50 мВт; \eta_{21} = 125...250; f_T = 4 ГГц$	SOT323, SC70	B-E-C
R7	BFR106	PHIL	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 700 мВт; \eta_{21} = 25...250; f_T = 5000 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
R7	BZX84C8V2T	DIODS	dz	$V_{Z(IZT=5 мА)} = 7.7...8.9 В; Z_{T(ZT=5 мА)} < 15 Ом$	SOT523	A-n.c.-K
R7s	BFR106	SIEM	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 700 мВт; \eta_{21} = 25...250; f_T = 5000 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
R8	BZX84C9V1T	DIODS	dz	$V_{Z(IZT=5 мА)} = 8.5...9.6 В; Z_{T(ZT=5 мА)} < 15 Ом$	SOT523	A-n.c.-K
R9	1SS392	TOSH	shd-2	$V_R = 40 В; V_F(I_F = 100 мА) < 0.6 В; I_n(V_R = 40 В) < 5 мкА; C_T < 25 пФ$	SOT346, SC59	A1-A2-K1, K2
R9	1SS393	TOSH	shd-2	$V_R = 40 В; I_F < 100 мА; V_F(I_F = 100 мА) < 0.6 В; C_D = 18 пФ$	SOT323, SC70	A1-A2-K1, K2
R9	BZX84C10T	DIODS	dz	$V_{Z(IZT=5 мА)} = 9.4...10.6 В; Z_{T(ZT=5 мА)} < 20 Ом$	SOT523	A-n.c.-K
R93	SST1S93	ROHM	pnnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 800 мА; \eta_{21} = 100...300; f_T > 50 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
R97	SST1S97	ROHM	npn	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 500 мА; \eta_{21} = 250...800$	SOT323, SOD23	B-E-C
R97	SST1S97	ROHM	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 200 мА; \eta_{21} = 250...700$	SOT23, SOD23	B-E-C
RA	RN2421	TOSH	Dpnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 800 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 1/1 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
RA4	BAV70	VISH	di-2	$V_R = 100 В; I_F = 300 мА; P_D = 350 мВт; t_{95\%} < 6 нс$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
RA6	BAS16	VISH	shd	$V_R = 100 В; I_F = 500 мА; P_D = 350 мВт; t_{95\%} < 4 нс$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
RA7	BAV99	VISH	di-2	$V_R = 100 В; I_F = 300 мА; P_D = 350 мВт; t_{95\%} < 6 нс$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
RA7	BAV99	ROHM	di-2	$V_R = 75 В; I_F < 450 мА; V_F(I_F = 150 мА) < 1.25 В; I_n < 2.5 мкА; t_{95\%} < 4 нс$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
RAA	ADR510ART	AD	vref	$I_{IN} = 0.1...10 мА; V_{OUT} = 1 В$	SOT23, SOD23	V+/-TRIM/n.c.
RAB	MMBD4448	VISH	shd	$V_R = 100 В; I_F = 500 мА; P_D = 350 мВт; t_{95\%} < 4 нс$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
RAF	SST2A29	ROHM	npn	$V_{CE0} = 100 В; I_C = 500 мА; \eta_{21} = 10000; f_T > 125 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
RAs	BFQ81	SIEM	npn	$V_{CE0} = 25 В; I_C = 30 мА; P_D = 280 мВт; \eta_{21} = 50...200; f_T = 5800 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
RAT	MM52A28	ROHM	dnpnp	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 500 мА; \eta_{21} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
RAT	MM52A28	ROHM	dnpnp	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 500 мА; \eta_{21} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
RAT	SST2A28	ROHM	npn	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 500 мА; \eta_{21} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
RAV	BAS16	VISH	shd	$V_R = 100 В; I_F = 500 мА; P_D = 350 мВт; t_{95\%} < 4 нс$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
RB	BZX84C2V4T	DIODS	dz	$V_{Z(IZT=5.0 мА)} = 2.2...2.6 В; I_n(V_R = 1.0 В) < 50 мкА; Z_{T(ZT=5.0 мА)} < 100 Ом; I_{ZM} = 200 мА$	SOT523	A-n.c.-K
RB	MSC1621	MOT	npn	$V_{CE0} = 20 В; f_T = 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
RB	RN2422	TOSH	Dpnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 800 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 2.2/2.2 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
RBA	ADR280AKS	AD	vref	$V_{IN} = 2.4...5.5 В; I_{IN} < 16 мкА; V_{OUT} = 1.2 В$	SOT323, SC70	VOUТ-VIN-GND
RBA	ADR280ART	AD	vref	$V_{IN} = 2.4...5.5 В; I_{IN} < 16 мкА; V_{OUT} = 1.2 В$	SOT23, SOD23	VIN-VOUT-GND
RBA	BAV99	VISH	di-2	$V_R = 100 В; I_F = 300 мА; P_D = 350 мВт; t_{95\%} < 6 нс$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
RBQ	SST7208	ROHM	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 100 мА; \eta_{21} > 100; f_T > 180 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
RBR	MM5T6838	ROHM	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 200 мА; \eta_{21} > 200; f_T > 50 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
RBR	SST6838	ROHM	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 200 мА; \eta_{21} > 100; f_T > 50 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
RBs	BF771	SIEM	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 80 мА; P_D = 580 мВт; \eta_{21} = 50...200; f_T = 8000 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
RBs	BF771W	SIEM	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 80 мА; P_D = 400 мВт; \eta_{21} = 50...200; f_T = 8000 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
RC	2SC2618C	REN	npn	$V_{CE0} = 35 В; I_C = 500 мА; P_D = 150 мВт; \eta_{21} = 100...200$	SOT23, SOD23	B-E-C
RC	BZX84C2V7T	DIODS	dz	$V_{Z(IZT=5 мА)} = 2.51...2.89 В; Z_{T(ZT=5 мА)} < 100 Ом$	SOT523	A-n.c.-K
RC	RN2423	TOSH	Dpnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 800 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7/4.7 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
RCs	BFR193	SIEM	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 80 мА; P_D = 580 мВт; \eta_{21} = 50...200; f_T = 8000 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
RCs	BFR193T	SIEM	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 80 мА; P_D = 580 мВт; \eta_{21} = 50...200; f_T = 8000 МГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
RCs	BFR193W	SIEM	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 80 мА; P_D = 580 мВт; \eta_{21} = 50...200; f_T = 8000 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
RD	2SC2618D	REN	npn	$V_{CE0} = 35 В; I_C = 500 мА; P_D = 150 мВт; \eta_{21} = 160...320$	SOT23, SOD23	B-E-C
RD	BZX84C3V0T	DIODS	dz	$V_{Z(IZT=5.0 мА)} = 2.8...3.2 В; Z_{T(ZT=5.0 мА)} < 100 Ом$	SOT523	A-n.c.-K
RD	RN2424	TOSH	Dpnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 800 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 10/10 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
RDs	BFR180	SIEM	npn	$V_{CE0} = 10 В; I_C = 4 мА; P_D = 30 мВт; \eta_{21} = 30...200; f_T = 6200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
RDs	BFR180W	SIEM	npn	$V_{CE0} = 10 В; I_C = 4 мА; P_D = 30 мВт; \eta_{21} = 30...200; f_T = 7000 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
RE	2SA1514KE	ROHM	pnnp	$V_{CE0} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; \eta_{21} = 390...820; f_T > 140 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
RE	2SA1579E	ROHM	pnnp	$V_{CE0} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; \eta_{21} = 390...820; f_T > 140 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
RE	BZX84C2V4T	DIODS	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5.0 \text{ mA})=2.2...2.6 \text{ B}$; $I_V(V_R=1.0 \text{ B}) < 50 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{Z1}=5.0 \text{ mA}) < 100 \text{ Ом}$; $I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT523	A-n.c.-K
RE	RN2425	TOSH	Dnpn	$V_{CE0}=50 \text{ B}$; $I_C=800 \text{ mA}$; $P_D=200 \text{ мВт}$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_{\theta J/P_2}=0.47/1.10 \text{ K/см}$	SOT346,SC59	B-E-C
REs	BFR280	SIEM	npn	$V_{CE0}=10 \text{ B}$; $I_C=10 \text{ mA}$; $P_D=80 \text{ мВт}$; $h_{21}=30...200$; $f_T=7500 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
REs	BFR280W	SIEM	npn	$V_{CE0}=10 \text{ B}$; $I_C=10 \text{ mA}$; $P_D=80 \text{ мВт}$; $h_{21}=30...200$; $f_T=7500 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
REs	BFR280W	SIEM	npn	$V_{CE0}=10 \text{ B}$; $I_C=10 \text{ mA}$; $P_D=80 \text{ мВт}$; $h_{21}=30...200$; $f_T=7500 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
RF	BFR181T	TELEF	npn	$V_{CE0}=20 \text{ B}$; $I_C=20 \text{ mA}$; $P_D=175 \text{ мВт}$; $h_{21} > 50$; $f_T=8 \text{ ГГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
RF	BZX84C3V6T	DIODS	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5 \text{ mA})=3.4...3.8 \text{ B}$; $Z_{T1}(I_{Z1}=5 \text{ mA}) < 95 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
RF	RN2426	TOSH	Dnpn	$V_{CE0}=50 \text{ B}$; $I_C=800 \text{ mA}$; $P_D=200 \text{ мВт}$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_{\theta J/P_2}=1/1.10 \text{ K/см}$	SOT346,SC59	B-E-C
RFQ	SST6839	ROHM	pnnp	$V_{CE0}=50 \text{ B}$; $I_C=200 \text{ mA}$; $h_{21} > 100$; $f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
RFQ	SST6839	ROHM	pnnp	$V_{CE0}=50 \text{ B}$; $I_C=200 \text{ mA}$; $h_{21} > 100$; $f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT346,SC59	B-E-C
RFs	BFR181	SIEM	npn	$V_{CE0}=15 \text{ B}$; $I_C=20 \text{ mA}$; $P_D=160 \text{ мВт}$; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
RFs	BFR181W	SIEM	npn	$V_{CE0}=20 \text{ B}$; $I_C=20 \text{ mA}$; $P_D=175 \text{ мВт}$; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
RG	BZX84C3V9T	DIODS	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5 \text{ mA})=3.7...4.1 \text{ B}$; $Z_{T1}(I_{Z1}=5 \text{ mA}) < 90 \text{ Ом}$	SOT523	A-n.c.-K
RG	RN2427	TOSH	Dnpn	$V_{CE0}=50 \text{ B}$; $I_C=800 \text{ mA}$; $P_D=200 \text{ мВт}$; $f_T > 250 \text{ МГц}$; $R_{\theta J/P_2}=2.2/1.10 \text{ K/см}$	SOT346,SC59	B-E-C
RGs	BFR182	SIEM	npn	$V_{CE0}=20 \text{ B}$; $I_C=35 \text{ mA}$; $P_D=250 \text{ мВт}$; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
RGs	BFR182T	SIEM	npn	$V_{CE0}=20 \text{ B}$; $I_C=35 \text{ mA}$; $P_D=250 \text{ мВт}$; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000 \text{ МГц}$	SOT416,SC75A	B-E-C
RGs	BFR182W	SIEM	npn	$V_{CE0}=20 \text{ B}$; $I_C=35 \text{ mA}$; $P_D=250 \text{ мВт}$; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
RH	BZX84C4V3T	DIODS	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5 \text{ mA})=4.0...4.6 \text{ B}$; $Z_{T1}(I_{Z1}=5 \text{ mA}) < 90 \text{ Ом}$	SOT523	A-n.c.-K
RHs	BFR183	SIEM	npn	$V_{CE0}=20 \text{ B}$; $I_C=65 \text{ mA}$; $P_D=450 \text{ мВт}$; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
RHs	BFR183T	SIEM	npn	$V_{CE0}=20 \text{ B}$; $I_C=65 \text{ mA}$; $P_D=450 \text{ мВт}$; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000 \text{ МГц}$	SOT416,SC75A	B-E-C
RHs	BFR183W	SIEM	npn	$V_{CE0}=20 \text{ B}$; $I_C=65 \text{ mA}$; $P_D=450 \text{ мВт}$; $h_{21}=50...200$; $f_T=8000 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
RJ	MCP101T-270/TT	MCHIP	mrnc	$V_{TR}=2.625 \text{ B}$; $V_{DD}=1.5...5.5 \text{ B}$; $I_{DD} < 60 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	RST-VDD-VSS
RK	MCP101T-300/TT	MCHIP	mrnc	$V_{TR}=2.925 \text{ B}$; $V_{DD}=1.5...5.5 \text{ B}$; $I_{DD} < 60 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	RST-VDD-VSS
RKs	BFR194	SIEM	pnnp	$V_{CE0}=20 \text{ B}$; $I_C=100 \text{ mA}$; $P_D=700 \text{ мВт}$; $h_{21}=20...150$; $f_T=5000 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
RKs	RK7002A	ROHM	nMOS	$V_{DS}=60 \text{ B}$; $I_D=300 \text{ mA}$; $P_D=200 \text{ мВт}$; $R_{\theta J/S(0.5 \text{ см})} < 1.5 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	G-S-D
RL	MCP101T-315/TT	MCHIP	mrnc	$V_{TR}=3.075 \text{ B}$; $V_{DD}=1.5...5.5 \text{ B}$; $I_{DD} < 60 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	RST-VDD-VSS
RM	MCP101T-450/TT	MCHIP	mrnc	$V_{TR}=4.375 \text{ B}$; $V_{DD}=1.5...5.5 \text{ B}$; $I_{DD} < 60 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	RST-VDD-VSS
RN	MCP101T-460/TT	MCHIP	mrnc	$V_{TR}=4.475 \text{ B}$; $V_{DD}=1.5...5.5 \text{ B}$; $I_{DD} < 60 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	RST-VDD-VSS
RP	MCP101T-485/TT	MCHIP	mrnc	$V_{TR}=4.725 \text{ B}$; $V_{DD}=1.5...5.5 \text{ B}$; $I_{DD} < 60 \text{ мкА}$	SOT23,SOD23	RST-VDD-VSS
RR	2SA1514KR	ROHM	pnnp	$V_{CE0}=120 \text{ B}$; $I_C=50 \text{ mA}$; $P_D=200 \text{ мВт}$; $h_{21}=180...390$; $f_T > 140 \text{ МГц}$	SOT346,SC59	B-E-C
RR	2SA1579R	ROHM	pnnp	$V_{CE0}=120 \text{ B}$; $I_C=50 \text{ mA}$; $P_D=200 \text{ мВт}$; $h_{21}=180...390$; $f_T > 140 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
RRA	BC847AF	AUK	npn	$V_{CE0}=50 \text{ B}$; $I_C=100 \text{ mA}$; $P_D=200 \text{ мВт}$; $h_{21}=110...220$; $f_T=150 \text{ МГц}$	SOT490,SC89	B-E-C
RRB	BC847BF	AUK	npn	$V_{CE0}=50 \text{ B}$; $I_C=100 \text{ mA}$; $P_D=200 \text{ мВт}$; $h_{21}=200...450$; $f_T=150 \text{ МГц}$	SOT490,SC89	B-E-C
RRC	BC847CF	AUK	npn	$V_{CE0}=50 \text{ B}$; $I_C=100 \text{ mA}$; $P_D=200 \text{ мВт}$; $h_{21}=420...800$; $f_T=150 \text{ МГц}$	SOT490,SC89	B-E-C
RS	2SA1514KS	ROHM	pnnp	$V_{CE0}=120 \text{ B}$; $I_C=50 \text{ mA}$; $P_D=200 \text{ мВт}$; $h_{21}=270...560$; $f_T > 140 \text{ МГц}$	SOT346,SC59	B-E-C
RS	2SA1579S	ROHM	pnnp	$V_{CE0}=120 \text{ B}$; $I_C=50 \text{ mA}$; $P_D=200 \text{ мВт}$; $h_{21}=270...560$; $f_T > 140 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
RSR	SST5210	ROHM	pnnp	$V_{CE0}=50 \text{ B}$; $I_C=200 \text{ mA}$; $h_{21}=200...600$; $f_T > 30 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
RT3	2SC4400	SANYO	npn	$V_{CE0}=40 \text{ B}$; $I_C=50 \text{ mA}$; $P_D=150 \text{ мВт}$; $h_{21}=60...120$; $f_T > 750 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
RT4	2SC4400	SANYO	npn	$V_{CE0}=40 \text{ B}$; $I_C=50 \text{ mA}$; $P_D=150 \text{ мВт}$; $h_{21}=90...180$; $f_T > 750 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
RT5	2SC4400	SANYO	npn	$V_{CE0}=40 \text{ B}$; $I_C=50 \text{ mA}$; $P_D=150 \text{ мВт}$; $h_{21}=135...270$; $f_T > 750 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
RVX	MMST918	ROHM	npn	$V_{CE0}=30 \text{ B}$; $I_C=50 \text{ mA}$; $h_{21} > 20...650$; $f_T=600 \text{ МГц}$	SOT346,SC59	B-E-C
RVZ	MMST4126	ROHM	pnnp	$V_{CE0}=25 \text{ B}$; $I_C=200 \text{ mA}$; $h_{21}=120...360$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
RVZ	MMST4126	ROHM	pnnp	$V_{CE0}=25 \text{ B}$; $I_C=200 \text{ mA}$; $h_{21}=120...360$; $f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT346,SC59	B-E-C
RX7	SST6426	ROHM	npn	$V_{CE0}=40 \text{ B}$; $I_C=500 \text{ mA}$; $h_{21}=300...300000$	SOT23,SOD23	B-E-C
RZC	MMST4124	ROHM	npn	$V_{CE0}=30 \text{ B}$; $I_C=200 \text{ mA}$; $h_{21}=120...360$; $f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT346,SC59	B-E-C
RZC	SST4124	ROHM	npn	$V_{CE0}=30 \text{ B}$; $I_C=200 \text{ mA}$; $h_{21}=120...360$; $f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
RZQ	MMST7157	ROHM	pnnp	$V_{CE0}=60 \text{ B}$; $I_C=200 \text{ mA}$; $h_{21} > 100$	SOT23,SOD23	B-E-C
S0	HSPM3880	HP	pin	$I_C < 1 \text{ A}$; $P_D < 250 \text{ мВт}$; $V_{DS} > 100 \text{ B}$; $R_{\theta J} < 6.5 \text{ Ом}$; $CT < 0.40 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
S0	SST270	SIL	pVET	$V_{GS}=30 \text{ B}$; $P_D=350 \text{ мВт}$; $g_f=6 \text{ мСм}$; $I_{DSS}=2...15 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	D-S-G
S1	BBV31	PHIL	var	$V_A < 30 \text{ B}$; $I_C < 20 \text{ mA}$; $I_B < 10 \text{ mA}$; $R_B < 1.2 \text{ Ом}$; $C_{1B} < 16.5 \text{ нФ}$; $C_{2B} < 1.6...2 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
S1	HSPM3881	HP	pin	$I_C < 1 \text{ A}$; $P_D < 250 \text{ мВт}$; $V_{DS} > 100 \text{ B}$; $R_{\theta J} < 6.5 \text{ Ом}$; $CT < 0.40 \text{ нФ}$	SOT23,SOD23	n.c.-A-K

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
S1	SS2721	SIL	pFET	$V_{DS} < 30 \text{ В}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{DSS} = 6...50 \text{ мА}; Q_g < 0.5 \text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
S12	BBY39	PHIL	var-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; C_{1B} = 16.5 \text{ нФ}; C_{2B} = 1.6...2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1,K2
S13	BBY42	PHIL	var	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_R < 10 \text{ мА}; R_{S} < 1 \text{ Ом}; C_{1B} > 31 \text{ нФ}; C_{2B} = 2.4...3 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
S14	BB901	PHIL	var	$V_R < 28 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_R < 10 \text{ мА}; R_{S} < 3 \text{ Ом}; C_{2B} = < 1.055 \text{ нФ}; C_{0.5B} / C_{2B} > 12$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
S14	SST5114	SIL	pFET	$V_{DS} < 30 \text{ В}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{DSS} = 30...90 \text{ мА}; R_{DS(on)} < 75 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
S15	SST5115	SIL	pFET	$V_{DS} < 30 \text{ В}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{DSS} = 15...60 \text{ мА}; R_{DS(on)} < 100 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
S16	SST5116	SIL	pFET	$V_{DS} < 30 \text{ В}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{DSS} = 5...25 \text{ мА}; R_{DS(on)} < 150 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
S16	ZHCS1006	ZETEX	shd	$V_R < 60 \text{ В}; I_R < 0.9 \text{ А}; V_{F1}(I_F = 1 \text{ А}) < 0.6 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мкА}; C_D < 17 \text{ пФ}; t_{TRR} < 12 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
s1A	SMBT3904	SIEM	nnp	$V_{CES} < 60 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s1B	PXTA93	SIEM	pnp	$V_{CES} < 200 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 1000 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s1B	SMBT2222	SIEM	nnp	$V_{CES} < 60 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s1C	SMBTA20	SIEM	nnp	$V_{CES} < 40 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 40...400; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s1D	SMBTA42	SIEM	nnp	$V_{CES} < 300 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 360 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s1E	SMBTA43	SIEM	nnp	$V_{CES} < 200 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 360 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s1G	SMBTA06	SIEM	nnp	$V_{CES} < 80 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s1H	SMBTA05	SIEM	nnp	$V_{CES} < 60 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s1K	SMBT6428	SIEM	nnp	$V_{CES} < 60 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 250...650; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s1L	SMBT6429	SIEM	nnp	$V_{CES} < 55 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 500...1250; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s1M	SMBTA13	SIEM	nnp	$V_{CES} < 30 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 5000; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s1N	SMBTA14	SIEM	nnp	$V_{CES} < 30 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 10000; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s1P	SMBT2222A	SIEM	nnp	$V_{CES} < 75 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s1V	SMBT6427	SIEM	nnp	$V_{CES} < 40 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 360 \text{ мВт}; h_{FE1} = 20000...200000; f_T > 130 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
S2	BBY40	PHIL	var	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_R < 10 \text{ мА}; R_{S} < 0.7 \text{ Ом}; C_{1B} = 26...32 \text{ нФ}; C_{2B} = 4.3...6 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
S2	BFQ31	ZETEX	nnp	$V_{CES} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 20; f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
S2	KTA2014	KEC	pnp	$V_{CES} < 50 \text{ В}; I_C < 150 \text{ мА}; P_D < 100 \text{ мВт}; h_{FE1} = 70...140; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
s2A	SMBT3906	SIEM	pnp	$V_{CES} < 40 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s2B	SMBT2907	SIEM	pnp	$V_{CES} < 40 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s2C	SMBTA70	SIEM	pnp	$V_{CES} < 40 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 40...400; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s2D	SMBTA92	SIEM	pnp	$V_{CES} < 300 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 360 \text{ мВт}; h_{FE1} > 25; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s2E	SMBTA93	SIEM	pnp	$V_{CES} < 200 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 360 \text{ мВт}; h_{FE1} > 25; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s2F	SMBT2907A	SIEM	pnp	$V_{CES} < 60 \text{ В}; I_C < 600 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s2G	SMBTA56	SIEM	pnp	$V_{CES} < 80 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s2H	SMBTA55	SIEM	pnp	$V_{CES} < 60 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s2P	SMBT5086	SIEM	pnp	$V_{CES} < 50 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 150...500; f_T > 40 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s2Q	SMBT5087	SIEM	pnp	$V_{CES} < 50 \text{ В}; I_C < 50 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 250...800; f_T > 40 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s2U	SMBTA63	SIEM	pnp	$V_{CES} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 360 \text{ мВт}; h_{FE1} > 5000; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
s2V	SMBTA64	SIEM	pnp	$V_{CES} < 30 \text{ В}; I_C < 500 \text{ мА}; P_D < 360 \text{ мВт}; h_{FE1} > 10000; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
S3	BBY51	SIEM	var-2	$V_R < 7 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_R < 0.01 \text{ мА}; C_{1B} = 4.5...6.1 \text{ нФ}; C_{1B} / C_{1B} = 1.55...2.2$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1,K2
S3	BFQ31R	ZETEX	nnp	$V_{CES} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 20; f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
S3s	BBY51	INF	var-2	$V_R < 7 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_R < 0.01 \text{ мА}; C_{1B} = 5.05...5.75 \text{ нФ}; C_{1B} > 2.5...3.7 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1,K2
S4	BFQ31A	ZETEX	nnp	$V_{CES} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
S4	KTA2014	KEC	pnp	$V_{CES} < 50 \text{ В}; I_C < 150 \text{ мА}; P_D < 100 \text{ мВт}; h_{FE1} = 120...240; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
S4	SST174	SIL	pFET	$V_{DS} < 30 \text{ В}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{DSS} = 20...135 \text{ мА}; R_{DS(on)} < 85 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
S5	BFQ31AR	ZETEX	nnp	$V_{CES} < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; P_D < 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; f_T > 600 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
S5	SST175	SIL	pFET	$V_{DS} < 30 \text{ В}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{DSS} = 7...70 \text{ мА}; R_{DS(on)} < 125 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D-S-G
S50	BS850	GS	pFET	$V_{DSS} < 60 \text{ В}; I_D < 250 \text{ мА}; P_D < 310 \text{ мВт}; V_{GS} < 20 \text{ В}$	SOT23, SOD23	G-S-D
s56	ZHCS506	ZETEX	shd	$V_R < 60 \text{ В}; I_R < 0.5 \text{ А}; V_{F1}(I_F = 0.5 \text{ А}) < 0.63 \text{ В}; I_R < 40 \text{ мкА}; C_D < 20 \text{ пФ}; t_{TRR} < 10 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
s5A	SMBD6050	SIEM	di	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; I_R < 0.1 \text{ мА}; C_D < 2.5 \text{ нФ}; t_{TRR} < 10 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
s5B	SMBD6100	SIEM	di-2	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; I_R < 0.1 \text{ мА}; C_D < 2.5 \text{ нФ}; t_{TRR} < 15 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1,K2



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
s5C	SMBD7000	SIEM	di-2	$V_R < 100 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В}; I_{R1} < 0.5 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 15 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1•K2•K1, A2
s5D	SMBD914	SIEM	di	$V_R < 70 \text{ В}; I_R < 250 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; I_{R1} < 0.025 \text{ мкА}; C_D < 2.0 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 4 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A•n.c. •K
S5s	BAT15-05W	INF	shd	$V_R < 4 \text{ В}; I_R < 110 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 10 \text{ мА}) < 0.41 \text{ В}; C_D < 0.35 \text{ нФ}$	SOT233, SC70	A1•A2•K1, K2
S5s	BBY52	SIEM	var-2	$V_R < 7 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_{R1} < 0.01 \text{ мкА}; C_{1B} = 1.1...2.5 \text{ нФ}; C_{1B}/C_{4B} = 1.1...2.1$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
S6	KTA2014	KEC	pnп	$V_{\text{CEO}} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D < 100 \text{ мВт}; \eta_{21} = 200...400; f_T > 80 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	B•E•C
S6	SST176	SIL	pFET	$V_{\text{DS}} = 30 \text{ В}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{\text{DSS}} = 2...35 \text{ мА}; R_{\text{DS(on)}} < 250 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D•S•G
S6p	BF510	PHIL	nFET	$V_{\text{DS}} = 20 \text{ В}; I_{\text{DS}} < 3 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; g_m = 2.5 \text{ мС}$	SOT23, SOD23	G•D•S
S7	SST177	SIL	pFET	$V_{\text{DS}} = 30 \text{ В}; P_D < 350 \text{ мВт}; I_{\text{DSS}} = 1.5...20 \text{ мА}; R_{\text{DS(on)}} < 300 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	D•S•G
S70	BS870	GS	nFET	$V_{\text{DSS}} = 60 \text{ В}; I_D = 250 \text{ мА}; P_D = 310 \text{ мВт}; V_{\text{GS}} < 20 \text{ В}$	SOT23, SOD23	G•S•D
S72	2N7002	VISH	nFET	$V_{\text{DS}} = 60 \text{ В}; I_D = 115 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; V_{\text{GS}} < 2.5 \text{ В}; C_{\text{ID}} = 60 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	G•S•D
S76	ZHCS756	ZETEX	shd	$V_R < 60 \text{ В}; I_R < 0.75 \text{ А}; V_{F1}(I_F = 0.75 \text{ А}) < 0.61 \text{ В}; I_{R1} < 100 \text{ мкА}; C_D < 17 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 12 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A•n.c. •K
S7p	BF511	PHIL	nFET	$V_{\text{DS}} = 20 \text{ В}; I_{\text{DS}} < 7 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; g_m = 4 \text{ мС}$	SOT23, SOD23	G•D•S
S7s	BBY53	INF	var-2	$V_R < 6 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_{R1} < 0.01 \text{ мкА}; C_{1B} = 4.8...5.8 \text{ нФ}; C_{1B} = 1.85...3.1 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
S7s	BBY53-05W	INF	var	$V_R < 6 \text{ В}; I_R < 20 \text{ мА}; I_{R1} < 0.01 \text{ мкА}; C_{1B} = 4.8...5.8 \text{ нФ}; C_{1B} = 1.85...3.1 \text{ нФ}$	SOT233, SC70	A1•A2•K1, K2
S8	BAT1504	SIEM	shd	$V_R < 4 \text{ В}; I_R < 110 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 10 \text{ мА}) < 0.48 \text{ В}; C_D < 0.35 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A•n.c. •K
S8p	BF512	PHIL	nFET	$V_{\text{DS}} = 20 \text{ В}; I_{\text{DS}} < 12 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; g_m = 6 \text{ мС}$	SOT23, SOD23	G•D•S
S8s	BAT15-04W	INF	shd	$V_R < 4 \text{ В}; I_R < 110 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 10 \text{ мА}) < 0.41 \text{ В}; C_D < 0.35 \text{ нФ}$	SOT233, SOT23	A1•K2•K1, A2
S9	1SS394	TOSH	shd	$V_R > 10 \text{ В}; V_{F1}(I_F = 100 \text{ мА}) < 0.5 \text{ В}; I_{R1}(V_R = 10 \text{ В}) < 20 \text{ мкА}; C_T < 40 \text{ нФ}$	SOT346, SC59	A•n.c. •K
S9	1SS395	TOSH	shd	$V_R > 10 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 100 \text{ мА}) < 0.5 \text{ В}; C_D < 40 \text{ нФ}$	SOT233, SOT23	A•n.c. •K
S9p	BF513	PHIL	nFET	$V_{\text{DS}} = 20 \text{ В}; I_{\text{DS}} < 18 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; g_m = 7 \text{ мС}$	SOT23, SOD23	G•D•S
SA	BSS123	ZETEX	nMOS	$V_{\text{DS}} = 100 \text{ В}; I_D = 170 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; g_m = 90 \text{ мСм}; R_{\text{DS(on)}} = 14 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G•S•D
sa2	SMBD2836	SIEM	di-2	$V_R = 50 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 4 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 6 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
sa3	SMBD2835	SIEM	di-2	$V_R = 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 4 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 6 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	K1•K2•A1, A2
sa4	SMBD2838	SIEM	di-2	$V_R = 50 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 4 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 6 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
sa5	SMBD2837	SIEM	di-2	$V_R = 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; V_{F1}(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}; I_{R1} < 0.1 \text{ мкА}; C_D < 4 \text{ нФ}; t_{\text{рег}} < 6 \text{ нс}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
SAs	BSS123	INF	nMOS	$V_{\text{DS}} = 100 \text{ В}; I_D = 170 \text{ мА}; P_D = 360 \text{ мВт}; g_m = 170 \text{ мСм}; R_{\text{DS(on)}} < 6 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G•S•D
SB	2SA1121B	REN	pnп	$V_{\text{CEO}} = 35 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; \eta_{21} = 60...120$	SOT23, SOD23	B•E•C
SBp	BB200	PHIL	var-2	$V_R < 18 \text{ В}; I_{R1}(V_R = 10 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}; C_{1B} = 65.8...74.2 \text{ нФ}; C_{4B}/C_{8B} = 12...14.8 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
SBs	BSS145	INF	nMOS	$V_{\text{DS}} = 65 \text{ В}; I_D = 220 \text{ мА}; P_D = 360 \text{ мВт}; g_m > 120 \text{ мСм}; R_{\text{DS(on)}} = 3.5 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G•S•D
SC	2SA1121C	REN	pnп	$V_{\text{CEO}} = 35 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; \eta_{21} = 100...200$	SOT23, SOD23	B•E•C
sC3	SMBT4126	SIEM	pnп	$V_{\text{CEO}} = 25 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; \eta_{21} = 120...360; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B•E•C
SCp	BB201	PHIL	var-2	$V_R > 15 \text{ В}; I_{R1}(V_R = 15 \text{ В}) < 0.2 \text{ мкА}; C_{1B} = 89...102 \text{ нФ}; C_{7,8B} = 25.5...29.7 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
SD	2SA1121D	REN	pnп	$V_{\text{CEO}} = 35 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; \eta_{21} = 100...320$	SOT23, SOD23	B•E•C
SDs	BSS284	INF	pMOS	$V_{\text{DS}} = 50 \text{ В}; I_D = 130 \text{ мА}; P_D = 360 \text{ мВт}; g_m > 50 \text{ мСм}; R_{\text{DS(on)}} = 10 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G•S•D
SF0	BB804	PHIL	var-2	$V_R < 18 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}; I_{R1} < 20 \text{ нА}; R_S < 0.2 \text{ Ом}; C_{2B} = 42...43.5 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{8B} > 1.65$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
SF0	BB804F0	SIEM	var-2	$V_R < 18 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}; I_{R1} < 0.02 \text{ мкА}; C_{2B} = 42...43.5 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{8B} > 1.65$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
SF1	BB804	PHIL	var-2	$V_R < 18 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}; I_{R1} < 20 \text{ нА}; R_S < 0.2 \text{ Ом}; C_{2B} = 43...44.5 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{8B} > 1.65$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
SF1	BB804F1	SIEM	var-2	$V_R < 18 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}; I_{R1} < 0.02 \text{ мкА}; C_{2B} = 43...44.5 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{8B} > 1.65$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
SF2	BB804	PHIL	var-2	$V_R < 18 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}; I_{R1} < 20 \text{ нА}; R_S < 0.2 \text{ Ом}; C_{2B} = 44...45.5 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{8B} > 1.65$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
SF2	BB804F2	SIEM	var-2	$V_R < 18 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}; I_{R1} < 0.02 \text{ мкА}; C_{2B} = 44...45.5 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{8B} > 1.65$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
SF2	BB804W	PHIL	var-2	$V_R < 18 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}; I_{R1} < 0.02 \text{ мкА}; C_{2B} = 42...46.5 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{8B} > 1.65$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
SF3	BB804	PHIL	var-2	$V_R < 18 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}; I_{R1} < 20 \text{ нА}; R_S < 0.2 \text{ Ом}; C_{2B} = 45...46.5 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{8B} > 1.65$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
SF3	BB804F3	SIEM	var-2	$V_R < 18 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}; I_{R1} < 0.02 \text{ мкА}; C_{2B} = 45...46.5 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{8B} > 1.65$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
SF4	BB804F4	SIEM	var-2	$V_R < 18 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}; I_{R1} < 0.02 \text{ мкА}; C_{2B} = 46...47.5 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{8B} > 1.65$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
SF5	BB804	PHIL	var-2	$V_R < 18 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}; I_{R1} < 0.02 \text{ мкА}; C_{2B} = 42...46.5 \text{ нФ}; C_{2B}/C_{8B} > 1.65$	SOT23, SOD23	A1•A2•K1, K2
SG	2SA1586	TOSH	pnп	$V_{\text{CEO}} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; \eta_{21} = 200...400; f_T = 80 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B•E•C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346 SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	К	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
SGR	KTA2014	KEC	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; h_{21} = 200...400; f_T > 80 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
SH1	BB814H1	INF	var-2	$V_A = 18 В; I_C < 50 мА; I_{FS} < 0.02 мкА; C_{2B} = 43...45 нФ; C_{2B}/C_{8B} = 2.05...2.25$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1,K2
SH2	BB814H2	INF	var-2	$V_A = 18 В; I_C < 50 мА; I_{FS} < 0.02 мкА; C_{2B} = 44.5...46.5 нФ; C_{2B}/C_{8B} = 2.05...2.25$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1,K2
SM	2SC3082KM	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 39...82; f_T > 110 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
SM	2SC4100M	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 39...82; f_T > 110 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
SM	2SC4619	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 39...82; f_T > 110 МГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
SMs	BB914	SIEM	var-2	$V_A < 18 В; I_C < 50 мА; I_{FS} < 0.02 мкА; C_{2B} = 42.5...45 нФ; C_{2B}/C_{8B} = 2.28...2.42$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1,K2
SN	2SC3082KN	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 110 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
SN	2SC4100N	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 110 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
SN	2SC4619	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 110 МГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
SO	2SA1586	TOSH	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; h_{21} > 70...140; f_T > 80 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
SO	KTA2014	KEC	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; h_{21} > 70...140; f_T > 80 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
SP	2SC3082KP	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 110 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
SP	2SC4100P	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 110 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
SP	2SC4619	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 110 МГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
SP	BSS84	ZETEX	pMOS	$V_{DS} = 50 В; I_D = 130 мА; P_D = 360 мВт; g_F = 50 мСм; R_{DS(on)} < 10 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
SPs	BSS84	SIEM	pMOS	$V_{DS} = 50 В; I_D = 130 мА; P_D = 360 мВт; g_F > 50 мСм; R_{DS(on)} < 10 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
SQ	2SC3082KQ	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 110 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
SQ	2SC4100Q	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 110 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
SQ	2SC4619	ROHM	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 110 МГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
SR	2SC3929R	PAN	npn	$V_{CE0} = 35 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 180...360; f_T = 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
SRs	BSS131	INF	nMOS	$V_{DS} = 240 В; I_D = 100 мА; P_D = 360 мВт; g_F = 140 мСм; R_{DS(on)} = 6 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
SS	2SC3929S	PAN	npn	$V_{CE0} = 35 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 260...520; f_T = 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
SS	BSS138	ZETEX	nMOS	$V_{DS} = 50 В; I_D = 200 мА; P_D = 360 мВт; g_F = 120 мСм; R_{DS(on)} = 6 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
sSF	SP0610T	SIEM	pMOS	$V_{DS} = 60 В; I_D = 130 мА; P_D = 360 мВт; g_F > 80 мСм; R_{DS(on)} < 10 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
sSG	SN7002	SIEM	nMOS	$V_{DS} = 60 В; I_D = 190 мА; P_D = 360 мВт; R_{DS(on)} < 7.5 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
sSH	BSS119	INF	nMOS	$V_{DS} = 100 В; I_D = 170 мА; P_D = 360 мВт; g_F > 100 мСм; R_{DS(on)} = 6 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
sSJ	BSS728	SIEM	nMOS	$V_{DS} = 60 В; I_D = 150 мА; P_D = 360 мВт; g_F = 80 мСм; R_{DS(on)} = 7.5 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
sSN	SN7002N	SIEM	nMOS	$V_{DS} = 60 В; I_D = 160 мА; P_D = 360 мВт; R_{DS(on)} < 7.5 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
sSd	SN7002N	SIEM	nMOS	$V_{DS} = 60 В; I_D = 180 мА; P_D = 500 мВт; R_{DS(on)} < 7.5 Ом$	SOT323, SC70	G-S-D
SSs	BSS138	INF	nMOS	$V_{DS} = 50 В; I_D = 220 мА; P_D = 360 мВт; g_F > 1200 мСм; R_{DS(on)} = 3.5 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
ST	2SC3929T	PAN	npn	$V_{CE0} = 35 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} = 360...700; f_T = 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
Sts	BSS139	INF	nMOS	$V_{DS} = 250 В; I_D = 40 мА; P_D = 360 мВт; g_F > 50 мСм; R_{DS(on)} < 10 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
SY	2SA1586	TOSH	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; h_{21} = 120...240; f_T > 80 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
SY	KTA2014	KEC	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; h_{21} = 120...240; f_T > 80 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
sZC	SiMBT4124	SIEM	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 200 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} = 120...360; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
T0	HSMS2860	HP	shd	$V_{RR} = 5 В; V_{F}(I_F = 30 мА) < 0.6 В; C_T < 0.30 пФ; R_D = 10 Ом$	SOT23, SOD23	A.n.c.-K
T0	HSMS2868	HP	shd	$V_{F}(I_F = 1 мА) < 0.35 В; C_T < 0.30 пФ$	SOT323, SC70	A.n.c.-K
T01	PDTA143ET	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 30; 4.7 кОм/4.7 кОм$	SOT23, SOD23	B-E-C
T01	PDTA143EU	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 30; 4.7 кОм/4.7 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
T02	PDTC143ET	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 30; 4.7 кОм/4.7 кОм$	SOT23, SOD23	B-E-C
T02	PDTC143EU	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 30; 4.7 кОм/4.7 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
T03	PDTA114ET	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 30; 10 кОм/10 кОм$	SOT23, SOD23	B-E-C
T03	PDTA114EU	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 30; 10 кОм/10 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
T04	PMSS3904	PHIL	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 200 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 180 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
T05	PDTA124ET	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 60; 22 кОм/22 кОм$	SOT23, SOD23	B-E-C
T05	PDTA124EU	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 60; 22 кОм/22 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
T05	SSTPAD5	CALOG	all	$V_A = 55 В; I_C < 10 мА; V_{F}(I_F = 1 мА) < 1.5 В; I_{FS} < 5 нА; C_T < 2 нФ$	SOT23, SOD23	K-K-A
T06	PDTC124EU	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 60; 22 кОм/22 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
T06	PMSS3906	PHIL	npn	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 200 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} = 100...300; f_T > 150 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
T07	PDTA144ET	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 80; 47 кОм/47 кОм$	SOT23, SOD23	B-E-C
T07	PDTA144EU	PHIL	Dnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 80; 47 кОм/47 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
108	PDTC144ET	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 80; 47 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	B-E-C
108	PDTC144EU	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 80; 47 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
109	PDTC114EU	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 30; 10 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
10KF	NDS0610	NS	rMOS	$V_{DS} = 60 \text{ В}; I_D = 120 \text{ мА}; P_D = 360 \text{ мВт}; R_{DS(on)} < 300 \text{ м}$	SOT23, SOD23	G-S-D
T1	BCX17	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_{C(sat)} < 100 \text{ нА}; h_{FE1} = 100...600; V_{CE(sat)} < 0.62 \text{ В}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T1	BCX17	CDIL	npn	$V_{CE0} = 45 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T1	BCX17	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T1	BSS63	MOT	npn	$V_{CE0} = 100 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 30; f_T = 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T1	HSMS2862	HP	shd-2	$V_{BR} > 5 \text{ В}; V_{F(I_F = 30 \text{ мА})} < 0.6 \text{ В}; C_T < 0.30 \text{ нФ}; R_D = 10 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
T10	SSTAD10	CALOG	di	$V_A = 55 \text{ В}; I_C < 10 \text{ мА}; V_{F(I_F = 1 \text{ мА})} < 1.5 \text{ В}; I_B < 10 \text{ нА}; C_T < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K-K-A
t11	PDTA114TT	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 200; R_1, 10 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T11	SSTAD100	CALOG	di	$V_A = 55 \text{ В}; I_C < 10 \text{ мА}; V_{F(I_F = 1 \text{ мА})} < 1.5 \text{ В}; I_B < 100 \text{ нА}; C_T < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K-K-A
t12	PDTC114TT	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 200; R_1, 10 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	B-E-C
t16	PDTC114ET	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 30; 10 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	B-E-C
t17	PDTC124ET	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 60; 22 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	B-E-C
t18	PDTC114TT	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	B-E-C
t19	PDTA1143TT	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	B-E-C
t1A	PMST3904	PHIL	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
T1B	LM61BIM3	NS	ats	$V_{A(sat)} = -25...85 \text{ } ^\circ\text{C}; V_{CE} = 2.7...10 \text{ В}; I_{OUT} < 10 \text{ мА}; \text{ACC} = \pm 4 \text{ } ^\circ\text{C}$	SOT23, SOD23	Vs-Vo-GND
t1B	PMBT2222	PHIL	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
t1B	PMST2222	PHIL	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	B-E-C
T1C	LM61CIM3	NS	ats	$V_{A(sat)} = -30...100 \text{ } ^\circ\text{C}; V_{CE} = 2.7...10 \text{ В}; I_{OUT} < 10 \text{ мА}; \text{ACC} = \pm 4 \text{ } ^\circ\text{C}$	SOT23, SOD23	Vs-Vo-GND
t1D	PMBTA42	PHIL	npn	$V_{CE0} = 300 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
t1D	PMSTA42	PHIL	npn	$V_{CE0} = 300 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	B-E-C
t1E	PMBTA43	MOT	npn	$V_{CE0} = 200 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
t1E	PMSTA43	PHIL	npn	$V_{CE0} = 200 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
t1F	PMBT5550	PHIL	npn	$V_{CE0} = 160 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 60...250; f_T = 100...300$	SOT23, SOD23	B-E-C
t1F	PMST5550	PHIL	npn	$V_{CE0} = 160 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} = 60...250; f_T = 100...300$	SOT323, SC70	B-E-C
t1H	MMBT405	PHIL	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
t1J	PMBT2369	PHIL	npn	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 40...120$	SOT23, SOD23	B-E-C
t1K	PMBT6428	PHIL	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 250...650; f_T = 100...700 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
t1L	PMBT6429	PHIL	npn	$V_{CE0} = 55 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 500...1250; f_T = 100...700 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
t1M	PMBTA13	PHIL	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 300 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 5000; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
t1N	PMBTA14	PHIL	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 300 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 10000; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T1p	BCX17	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
t1P	PMBT2222A	PHIL	npn	$V_{CE0} = 75 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
t1P	PMST2222A	PHIL	npn	$V_{CE0} = 75 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
t1Q	PMBT5088	PHIL	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 350...1400$	SOT23, SOD23	B-E-C
t1Q	PMST5088	PHIL	npn	$V_{CE0} = 35 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 300...900$	SOT323, SC70	B-E-C
t1R	PMST5089	PHIL	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 400...1200$	SOT323, SC70	B-E-C
T1t	BCX17	PHIL	npn	$V_{CE0} = 45 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T2	BCX18	ALLEG	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_{C(sat)} < 100 \text{ нА}; h_{FE1} = 100...600; V_{CE(sat)} < 0.62 \text{ В}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T2	BCX18	CDIL	npn	$V_{CE0} = 25 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T2	BCX18	ZETEX	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T2	HSMS286C	HP	shd-2	$V_{F(I_F = 1 \text{ мА})} < 0.35 \text{ В}; C_T < 0.30 \text{ нФ}$	SOT323, SOD23	A1-K2-K1, A2
T2	TN2460T	SIL	rMOS	$V_{DS} = 240 \text{ В}; I_D = 51 \text{ мА}; P_D = 360 \text{ мВт}; g_m = 70 \text{ мСм}; R_{DS(on)} = 11 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
T20	SSTAD20	CALOG	di	$V_A = 55 \text{ В}; I_C < 10 \text{ мА}; V_{F(I_F = 1 \text{ мА})} < 1.5 \text{ В}; I_B < 20 \text{ нА}; C_T < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K-K-A
T21	SSTAD200	CALOG	di	$V_A = 55 \text{ В}; I_C < 10 \text{ мА}; V_{F(I_F = 1 \text{ мА})} < 1.5 \text{ В}; I_B < 200 \text{ нА}; C_T < 2 \text{ нФ}$	SOT23, SOD23	K-K-A
t23	PDTA114TU	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 200; R_1, 10 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
t24	PDTC114TU	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 200; R_1, 10 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
t27	PDTC114YT	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; 10 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	B-E-C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346 SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
I28	PDTA114WU	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 60; 47 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
I29	PDTA114YT	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; 10 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT323, SOD23	B-E-C
I2A	PMBT3906	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
I2B	PMST3906	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
I2A	PMBT2907	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 30; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
I2D	PMBTA92	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 300 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
I2D	PMSTA92	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 300 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
I2E	PMBTA93	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 200 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
I2E	PMSTA93	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 200 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
I2F	PMBT2907A	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
I2G	PMBTA56	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 80 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
I2G	PMSTA56	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 80 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
I2H	PMBTA55	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
I2H	PMSTA55	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; f_T > 50 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
I2L	PMBT5401	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 160 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 60...240; f_T = 100...300 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
I2L	PMBT5401	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 160 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} = 60...240; f_T = 100...300 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
I2P	BCX18	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 25 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; 600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
T21	BCX18	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 25 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...600; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
I2T	PMBT4403	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
I2T	PMST4403	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
I2U	PMBTA63	PHIL	drnp	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 5000; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
I2V	PMBTA64	PHIL	drnp	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 10000; f_T > 125 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
I2X	PMBT4401	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
I2X	PMST4401	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...300; f_T > 250 \text{ МГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
T3	BSS63	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 100 \text{ В}; I_C = 800 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} > 30; f_T = 150 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
T3	HSMS2863	HP	shd-2	$V_{BE1} = 5 \text{ В}; V_{CE1} = 30 \text{ мА} < 0.6 \text{ В}; C_T < 0.30 \text{ нФ}; R_D = 10 \text{ Ом}$	SOT323, SOD23	K1-K2; A1, A2
T3	HSMS286E	HP	shd-2	$V_{BE1} = 1 \text{ мА} < 0.35 \text{ В}; C_T < 0.30 \text{ нФ}$	SOT323, SC70	K1-K2; A1, A2
I30	PDTC114YU	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; 10 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
I31	PDTA143XT	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; 4.7 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT323, SOD23	B-E-C
T32	2SC4182	NEC	rnp	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 160 \text{ мВт}; h_{FE1} = 60...105; f_T = 1.1 \text{ ГГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
I32	PDTC143XT	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; 4.7 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT323, SOD23	B-E-C
T33	2SC4182	NEC	rnp	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 160 \text{ мВт}; h_{FE1} = 85...150; f_T = 1.1 \text{ ГГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
T34	2SC4182	NEC	rnp	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 160 \text{ мВт}; h_{FE1} = 120...220; f_T = 1.1 \text{ ГГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
T35	BSR20	CDIL	rnp	$V_{CE0} = 130 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T = 400 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
T35	BSR20	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 130 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 40; f_T = 100...400 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
T36	BSR20A	CDIL	rnp	$V_{CE0} = 160 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 60; f_T = 300 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
T36	BSR20A	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 160 \text{ В}; I_C = 600 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 60; f_T = 100...300 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
T4	BCX17R	ZETEX	rnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
T4	BCX17R	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 45 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	C-B-E
T4	HSMS2864	HP	shd-2	$V_{BE1} = 5 \text{ В}; V_{CE1} = 30 \text{ мА} < 0.6 \text{ В}; C_T < 0.30 \text{ нФ}; R_D = 10 \text{ Ом}$	SOT323, SOD23	A1-A2; K1, K2
T4	HSMS286F	HP	shd-2	$V_{BE1} = 1 \text{ мА} < 0.35 \text{ В}; C_T < 0.30 \text{ нФ}$	SOT323, SC70	A1-A2; K1, K2
T42	2SC4184	NEC	rnp	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 160 \text{ мВт}; h_{FE1} = 40...80; f_T > 1.2 \text{ ГГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
T43	2SC4184	NEC	rnp	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 160 \text{ мВт}; h_{FE1} = 60...120; f_T > 1.2 \text{ ГГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
T44	2SC4184	NEC	rnp	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 160 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...200; f_T > 1.2 \text{ ГГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
I46	PDTA143XU	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; 4.7 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
I47	PDTA143ZU	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 100; 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
T4B	LM45BM3	NS	ats	$T_{AMB} = -20...100 \text{ }^\circ\text{C}; V_{CE2} = 4...10 \text{ В}; I_{OUT} < 10 \text{ мА}$	SOT323, SOD23	+Vs -Vo -GND
T4C	LM45CM3	NS	ats	$T_{AMB} = -20...100 \text{ }^\circ\text{C}; V_{CE2} = 4...10 \text{ В}; I_{OUT} < 10 \text{ мА}$	SOT323, SOD23	+Vs -Vo -GND
T5	BCX18R	ZETEX	rnp	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
T5	BCX18R	PHIL	rnp	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT323, SOD23	C-B-E
T50	SSTPAD50	CALOG	dl	$V_{BE1} = 55 \text{ В}; I_C < 10 \text{ мА}; V_{CE1} = 1 \text{ мА} < 1.5 \text{ В}; I_C < 50 \text{ нА}; C_T < 2 \text{ нФ}$	SOT323, SOD23	K1-KA
I53	PDTC143XU	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE1} > 50; 4.7 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3
t54	PDTС1432U	PHIL	Dnpn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 100; 4,7 кОм/47 кОм$	SOT323,SC70	В•Е•С
t55	PDTA114YU	PHIL	Dnpn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 100; 10 кОм/47 кОм$	SOT323,SC70	В•Е•С
t5B	LM50BIM3	NS	ats	$T_{AMB} = -40...125 °C; V_{CC} = 4.5...10 В; I_{OUL} < 10 мА; ACC = \pm 2 °C$	SOT23,SOD23	+Vs •Vo•GND
t5C	LM50CIM3	NS	ats	$T_{AMB} = -40...125 °C; V_{CC} = 4.5...10 В; I_{OUL} < 10 мА; ACC = \pm 3 °C$	SOT23,SOD23	+Vs •Vo•GND
t6	BSS63R	PHIL	npn	$V_{CBO} = 100 В; I_C = 600 мА; P_D = 330 мВт; h_{21} > 30; f_T = 150 МГц$	SOT23,SOD23	Е•В•С
t61	ZUMT617	ZETEX	npn	$V_{CBO} = 15 В; I_C = 1.5 А; P_D = 385 мВт; h_{21} > 30; f_T = 180 МГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t62	2SC3841P	NEC	npn	$V_{CBO} = 25 В; I_C = 30 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 40...80; f_T > 2.5 ГГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t62	2SC4186	NEC	npn	$V_{CBO} = 25 В; I_C = 30 мА; P_D = 160 мВт; h_{21} > 40...80; f_T > 2.5 ГГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t62	ZUMT618	ZETEX	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 1.25 А; P_D = 385 мВт; h_{21} > 20; f_T = 210 МГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t63	2SC3841Q	NEC	npn	$V_{CBO} = 25 В; I_C = 30 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 60...120; f_T > 2.5 ГГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t63	2SC4186	NEC	npn	$V_{CBO} = 25 В; I_C = 30 мА; P_D = 160 мВт; h_{21} > 60...120; f_T > 2.5 ГГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t63	ZUMT619	ZETEX	npn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 1 А; P_D = 385 мВт; h_{21} > 20; f_T = 215 МГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t64	2SC3841R	NEC	npn	$V_{CBO} = 25 В; I_C = 30 мА; P_D = 200 мВт; h_{21} > 100...200; f_T > 2.5 ГГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t64	2SC4186	NEC	npn	$V_{CBO} = 25 В; I_C = 30 мА; P_D = 160 мВт; h_{21} > 100...200; f_T > 2.5 ГГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t6B	LM60BIM3	NS	ats	$T_{AMB} = -25...125 °C; V_{CC} = 4.5...10 В; I_{OUL} < 10 мА; ACC = \pm 3 °C$	SOT23,SOD23	+Vs •Vo•GND
t6C	LM60CIM3	NS	ats	$T_{AMB} = -40...125 °C; V_{CC} = 4.5...10 В; I_{OUL} < 10 мА; ACC = \pm 4 °C$	SOT23,SOD23	+Vs •Vo•GND
t7	BSR15	CDIL	pnп	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 30; f_T = 200 МГц$	SOT23,SOD23	Е•В•С
t7	BSR15	SGS	pnп	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 30; f_T = 200 МГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t7	SST4117	SIL	nFET	$V_{GS} = 40 В; P_D = 350 мВт; I_{DSS} = 0.03...0.09 мА; g_m = 70 мСм$	SOT23,SOD23	Д•S•G
t71	BSR15R	SGS	pnп	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 30; f_T = 200 МГц$	SOT23,SOD23	Е•В•С
t71	ZUMT717	ZETEX	pnп	$V_{CBO} = 12 В; I_C = 1.25 А; P_D = 385 мВт; h_{21} > 30; f_T = 220 МГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t72	2SC4568	NEC	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 40...80; f_T = 5.5 ГГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t72	2SC4570	NEC	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 120 мВт; h_{21} > 40...80; f_T = 5.5 ГГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t72	ZUMT718	ZETEX	pnп	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 1 А; P_D = 385 мВт; h_{21} > 20; f_T = 210 МГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t73	2SC4568	NEC	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 60...120; f_T = 5.5 ГГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t73	2SC4570	NEC	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 120 мВт; h_{21} > 60...120; f_T = 5.5 ГГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t73	ZUMT719	ZETEX	pnп	$V_{CBO} = 40 В; I_C = 1 А$	SOT323,SC70	В•Е•С
t74	2SC4568	NEC	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100...200; f_T = 5.5 ГГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t74	2SC4570	NEC	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 120 мВт; h_{21} > 100...200; f_T = 5.5 ГГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t75	2SC4569	NEC	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 60 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 40...80; f_T = 5 ГГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t75	2SC4571	NEC	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 60 мА; P_D = 120 мВт; h_{21} > 40...80; f_T = 5 ГГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t75	NE58230	NEC	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 60 мА; P_D = 120 мВт; h_{21} > 40...80; f_T = 5 ГГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t76	2SC4569	NEC	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 60 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 60...120; f_T = 5 ГГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t76	2SC4571	NEC	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 60 мА; P_D = 120 мВт; h_{21} > 60...120; f_T = 5 ГГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t76	NE58230	NEC	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 60 мА; P_D = 120 мВт; h_{21} > 60...120; f_T = 5 ГГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t77	2SC4569	NEC	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 60 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 100...200; f_T = 5 ГГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t77	2SC4571	NEC	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 60 мА; P_D = 120 мВт; h_{21} > 100...200; f_T = 5 ГГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t77	NE58230	NEC	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 60 мА; P_D = 120 мВт; h_{21} > 100...200; f_T = 5 ГГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t7B	LM62BIM3	NS	ats	$T_{AMB} = 0...90 °C; V_{CC} = 2.7...10 В; I_{OUL} < 10 мА; ACC = \pm 2 °C$	SOT23,SOD23	+Vs •Vo•GND
t7C	LM62CIM3	NS	ats	$T_{AMB} = 0...90 °C; V_{CC} = 2.7...10 В; I_{OUL} < 10 мА; ACC = \pm 3 °C$	SOT23,SOD23	+Vs •Vo•GND
t7p	BSR15	PHIL	pnп	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 30; f_T > 200 МГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t71	BSR15	PHIL	pnп	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 30; f_T > 200 МГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
i7Y	PDTB123Y	PHIL	Dnpn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 70; 2.2 кОм/10 кОм$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t8	BSR16	CDIL	pnп	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 50; f_T > 200 МГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t8	BSR16	SGS	pnп	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 50; f_T > 200 МГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t8	SST4118	SIL	nFET	$V_{GS} = 40 В; P_D = 350 мВт; I_{DSS} = 0.08...0.24 мА; g_m = 80 мСм$	SOT23,SOD23	Д•S•G
t81	BSR16R	SGS	pnп	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 250 мВт; h_{21} > 50; f_T > 200 МГц$	SOT23,SOD23	Е•В•С
t82	2SC4954	NEC	npn	$V_{CBO} = 9 В; I_C = 10 мА; P_D = 60 мВт; h_{21} > 75...150; f_T = 12 ГГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t82	2SC4958	NEC	npn	$V_{CBO} = 9 В; I_C = 10 мА; P_D = 60 мВт; h_{21} > 75...150; f_T = 12 ГГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t83	2SC4955	NEC	npn	$V_{CBO} = 9 В; I_C = 30 мА; P_D = 180 мВт; h_{21} > 75...150; f_T = 12 ГГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С
t83	2SC4959	NEC	npn	$V_{CBO} = 9 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{21} > 75...100; f_T = 12 ГГц$	SOT323,SC70	В•Е•С
t84	2SC5177	NEC	npn	$V_{CBO} = 5 В; I_C = 10 мА; P_D = 30 мВт; h_{21} > 70...140; f_T > 10 ГГц$	SOT23,SOD23	В•Е•С

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
T84	2SC5179	NEC	npn	$V_{CE0}=5\text{ В}; I_C=10\text{ мА}; P_D=30\text{ мВт}; h_{FE}=70...140; f_T>10\text{ ГГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
T86	2SC5182	NEC	npn	$V_{CE0}=5\text{ В}; I_C=30\text{ мА}; P_D=90\text{ мВт}; h_{FE}=70...140; f_T>9\text{ ГГц}$	SOT323, SOD23	B-E-C
T88	2SC5184	NEC	npn	$V_{CE0}=5\text{ В}; I_C=30\text{ мА}; P_D=90\text{ мВт}; h_{FE}=70...140; f_T>9\text{ ГГц}$	SOT323, SC70	B-E-C
T86	2SC5191	NEC	npn	$V_{CE0}=9\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{FE}=80...160; f_T>4\text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T88	2SC5193	NEC	npn	$V_{CE0}=9\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{FE}=80...160; f_T>4\text{ ГГц}$	B-E-C	B-E-C
T8p	BSR16	PHIL	pnp	$V_{CE0}=60\text{ В}; I_C=600\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; h_{FE}>50; f_T>200\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T8t	BSR16	PHIL	pnp	$V_{CE0}=60\text{ В}; I_C=600\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; h_{FE}>50; f_T>200\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T9	1SS396	TOSH	shd-2	$V_{B0}=40\text{ В}; V_{F0}(I_F=100\text{ мА})<0.6\text{ В}; I_{S0}(V_{B0}=40\text{ В})<5\text{ мкА}; C_T<25\text{ пФ}$	SOT346, SC59	A1-K2-K1, A2
T9	SST4119	SIL	nFET	$V_{DS}=40\text{ В}; P_D=350\text{ мВт}; I_{DSS}=0.2...0.6\text{ мА}; g_{FS}=100\text{ мСм}$	SOT23, SOD23	D-S-G
T92	2SA1977	NEC	pnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{FE}=20...100; f_T>6\text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T92	BSR18A	CDIL	npn	$V_{CE0}=40\text{ В}; I_C=200\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; h_{FE}=100...300; f_T>250\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T92	BSR18A	FAIR	pnp	$V_{CE0}=40\text{ В}; I_C=200\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; h_{FE}=100...300; f_T>250\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T92	NE97733	NEC	pnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{FE}=20...100; f_T=8.5\text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T92p	BSR18A	PHIL	npn	$V_{CE0}=40\text{ В}; I_C=200\text{ мА}; P_D=250\text{ мВт}; h_{FE}=100...300; f_T>250\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T93	2SA1978	NEC	pnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{FE}=20...100; f_T>4\text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
T93	NE97833	NEC	pnp	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{FE}=20...100; f_T=5.5\text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
I9A	PLVA650A	PHIL	dz	$V_{F0}(I_{F0}=250\text{ мкА})=4.8...5.2\text{ В}; I_{V0}(V_{F0}=0.8^*V_{F0})<20\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{T1}=250\text{ мкА})<700\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
I9B	PLVA653A	PHIL	dz	$V_{F0}(I_{F0}=250\text{ мкА})=5.1...5.5\text{ В}; I_{V0}(V_{F0}=0.8^*V_{F0})<5\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{T1}=250\text{ мкА})<250\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
I9C	PLVA656A	PHIL	dz	$V_{F0}(I_{F0}=250\text{ мкА})=5.4...5.8\text{ В}; I_{V0}(V_{F0}=0.8^*V_{F0})<1\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{T1}=250\text{ мкА})<100\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
I9D	PLVA659A	PHIL	dz	$V_{F0}(I_{F0}=250\text{ мкА})=5.7...6.1\text{ В}; I_{V0}(V_{F0}=0.8^*V_{F0})<500\text{ нА}; Z_{T1}(I_{T1}=250\text{ мкА})<100\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
I9E	PLVA662A	PHIL	dz	$V_{F0}(I_{F0}=250\text{ мкА})=6.0...6.4\text{ В}; I_{V0}(V_{F0}=0.8^*V_{F0})<100\text{ нА}; Z_{T1}(I_{T1}=250\text{ мкА})<100\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
I9F	PLVA665A	PHIL	dz	$V_{F0}(I_{F0}=250\text{ мкА})=6.3...6.7\text{ В}; I_{V0}(V_{F0}=0.8^*V_{F0})<50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{T1}=250\text{ мкА})<100\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
I9G	PLVA668A	PHIL	dz	$V_{F0}(I_{F0}=250\text{ мкА})=6.6...7.0\text{ В}; I_{V0}(V_{F0}=0.8^*V_{F0})<10\text{ нА}; Z_{T1}(I_{T1}=250\text{ мкА})<100\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
I9J	PLVA2650A	PHIL	dz-2	$V_{F0}(I_{F0}=250\text{ мкА})=4.8...5.2\text{ В}; I_{V0}(V_{F0}=0.8^*V_{F0})<20\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{T1}=250\text{ мкА})<700\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
I9K	PLVA2653A	PHIL	dz-2	$V_{F0}(I_{F0}=250\text{ мкА})=5.1...5.5\text{ В}; I_{V0}(V_{F0}=0.8^*V_{F0})<5\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{T1}=250\text{ мкА})<250\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
I9L	PLVA2656A	PHIL	dz-2	$V_{F0}(I_{F0}=250\text{ мкА})=5.4...5.8\text{ В}; I_{V0}(V_{F0}=0.8^*V_{F0})<1\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{T1}=250\text{ мкА})<100\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
I9M	PLVA2659A	PHIL	dz-2	$V_{F0}(I_{F0}=250\text{ мкА})=5.7...6.1\text{ В}; I_{V0}(V_{F0}=0.8^*V_{F0})<500\text{ нА}; Z_{T1}(I_{T1}=250\text{ мкА})<100\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
I9N	PLVA2662A	PHIL	dz-2	$V_{F0}(I_{F0}=250\text{ мкА})=6.0...6.4\text{ В}; I_{V0}(V_{F0}=0.8^*V_{F0})<100\text{ нА}; Z_{T1}(I_{T1}=250\text{ мкА})<100\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
I9O	PLVA2665A	PHIL	dz-2	$V_{F0}(I_{F0}=250\text{ мкА})=6.3...6.7\text{ В}; I_{V0}(V_{F0}=0.8^*V_{F0})<50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{T1}=250\text{ мкА})<100\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
I9P	PLVA2668A	PHIL	dz-2	$V_{F0}(I_{F0}=250\text{ мкА})=6.6...7.0\text{ В}; I_{V0}(V_{F0}=0.8^*V_{F0})<10\text{ нА}; Z_{T1}(I_{T1}=250\text{ мкА})<100\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
TA	2SC5431EB	NEC	npn	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=60\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; h_{FE}=60...90; f_T>3\text{ ГГц}$	SC81, MFFPAK	B-E-C
TA	KTC3295A	KEC	npn	$V_{CE0}=60\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{FE}=600...1800; f_T>250\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
TA	NE582M03	NEC	npn	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=60\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; h_{FE}=60...90; f_T=4.3\text{ ГГц}$	SC81, MFFPAK	B-E-C
TA5	MMB215VDA	VISH	dz-2	$V_{F0}(I_{F0}=1\text{ мА})=14.7...15.3\text{ В}; V_{F0}(I_{F0}=200\text{ мА})<0.9\text{ В}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
TA7	MMB227VDA	VISH	dz-2	$V_{F0}(I_{F0}=1\text{ мА})=26.46...27.54\text{ В}; V_{F0}(I_{F0}=200\text{ мА})<1.1\text{ В}$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
TAA	BC856AF	AUK	pnp	$V_{CE0}=80\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{FE}=110...220; f_T=150\text{ МГц}$	SOT490, SC89	B-E-C
TAB	BC856BF	AUK	pnp	$V_{CE0}=80\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{FE}=200...450; f_T=150\text{ МГц}$	SOT490, SC89	B-E-C
TAC	BC856CF	AUK	pnp	$V_{CE0}=80\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{FE}=420...800; f_T=150\text{ МГц}$	SOT490, SC89	B-E-C
TB	2SC5431FB	NEC	npn	$V_{CE0}=20\text{ В}; I_C=60\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; h_{FE}=80...120; f_T>3\text{ ГГц}$	SC81, MFFPAK	B-E-C
TB	KTC3295B	KEC	npn	$V_{CE0}=60\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{FE}=1200...3600; f_T>250\text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
TBD	BAT46CW	STM	shd-2	$V_R=100\text{ В}; I_R<150\text{ мА}; V_{F0}(I_{F0}=10\text{ мА})<0.45\text{ мВ}; C_{D0}=10\text{ пФ}$	SOT323, SC70	A2-A1-K1, K2



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	БТМ	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
TBD	BAT465W	STM	shd-2	$V_A < 100 В; I_F < 150 мА; V_{CE(sat)}(I_F=10 мА) < 0.45 мВ; C_D = 10 пФ$	SOT323, SC70	A2-K1-A1, K2
TC	2SC2736	REN	npn	$V_{CE(sat)} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE1} = 30...200; f_T > 1.4 ГГц$	SOT346, SC59	B-E-C
TC	2SC5432EB	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 125 мВт; h_{FE1} = 80...110; f_T > 3 ГГц$	SC81, MFPK	B-E-C
TC5	MMBZ15VDC	VISH	dz-2	$V_{Z1(ZT)} = 1 МВ; I_Z = 14.3...15.8 мА; V_F(I_F=200 мА) < 0.9 В$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
TC7	MMBZ27VDC	VISH	dz-2	$V_{Z1(ZT)} = 1 МВ; I_Z = 26.65...28.35 мА; V_F(I_F=200 мА) < 1.1 В$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
TD	2SC5432FB	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 125 мВт; h_{FE1} = 100...145; f_T > 3 ГГц$	SC81, MFPK	B-E-C
TE	2SC3906KE	ROHM	npn	$V_{CE(sat)} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE1} = 390...820; f_T > 140 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
TE	2SC4102E	ROHM	npn	$V_{CE(sat)} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE1} = 390...820; f_T > 140 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
TE	2SC5433EB	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 125 мВт; h_{FE1} = 80...110; f_T > 4.5 ГГц$	SC81, MFPK	B-E-C
TF	2SC5433FB	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 20 В; I_C = 65 мА; P_D = 125 мВт; h_{FE1} = 100...145; f_T > 4.5 ГГц$	SC81, MFPK	B-E-C
tG1	PMBT5551	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} = 180 В; I_C = 600 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 80...250; f_T = 100...300$	SOT23, SOD23	B-E-C
tG3	PMT5551	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} = 180 В; I_C = 600 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE1} = 80...250; f_T = 100...300 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
TH	2SC5434FB	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 20 В; I_C = 35 мА; P_D = 125 мВт; h_{FE1} = 80...110; f_T > 5.5 ГГц$	SC81, MFPK	B-E-C
TI	2SC4197E	REN	npn	$V_{CE(sat)} = 25 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE1} = 50...180; f_T > 3 ГГц$	SOT346, SC59	B-E-C
TI	2SC4260	REN	npn	$V_{CE(sat)} = 25 В; I_C = 50 мА; P_D = 100 мВт; h_{FE1} = 50...180; f_T > 3 ГГц$	SOT323, SC70	B-E-C
TJ	2SC5434FB	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 20 В; I_C = 35 мА; P_D = 125 мВт; h_{FE1} = 100...145; f_T > 5.5 ГГц$	SC81, MFPK	B-E-C
TK	2SC5435EB	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 9 В; I_C = 30 мА; P_D = 125 мВт; h_{FE1} = 75...110; f_T = 12 ГГц$	SC81, MFPK	B-E-C
TL	2SC5435FB	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 9 В; I_C = 30 мА; P_D = 125 мВт; h_{FE1} = 95...140; f_T = 12 ГГц$	SC81, MFPK	B-E-C
TN	2SC5436EB	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 5 В; I_C = 30 мА; P_D = 90 мВт; h_{FE1} = 75...100; f_T = 9 ГГц$	SC81, MFPK	B-E-C
TO	TP0610T	TEMIC	pMOS	$V_{DS} = 60 В; I_D = 120 мА; P_D = 360 мВт; g_m = 60 мСм; R_{DS(on)} = 10 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
TO	TP0610T	SIL	pMOS	$V_{DS} = 60 В; I_D = 120 мА; P_D = 360 мВт; g_m = 60 мСм; R_{DS(on)} = 10 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
tO4	PMBS3904	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} = 60 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...300; f_T > 180 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
tO6	PMBS3906	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} = 40 В; I_C = 100 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...300; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
TP	2SC5436FB	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 5 В; I_C = 30 мА; P_D = 90 мВт; h_{FE1} = 90...130; f_T > 9 ГГц$	SC81, MFPK	B-E-C
TR	2SC3906KR	ROHM	npn	$V_{CE(sat)} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE1} = 180...390; f_T > 140 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
TR	2SC3929AR	PAN	npn	$V_{CE(sat)} = 55 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE1} = 180...360; f_T = 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
TR	2SC4102R	ROHM	npn	$V_{CE(sat)} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE1} = 180...390; f_T > 140 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
TS	2SC3906KS	ROHM	npn	$V_{CE(sat)} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE1} = 270...560; f_T > 140 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
TS	2SC3929AS	PAN	npn	$V_{CE(sat)} = 55 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE1} = 260...520; f_T = 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
TS	2SC4102S	ROHM	npn	$V_{CE(sat)} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE1} = 270...560; f_T > 140 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
TS	2SC5437EB	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 9 В; I_C = 100 мА; P_D = 125 мВт; h_{FE1} = 80...110; f_T > 4 ГГц$	SC81, MFPK	B-E-C
TT	2SC3929AT	PAN	npn	$V_{CE(sat)} = 55 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE1} = 360...700; f_T = 100 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C
TT	2SC5437FB	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 9 В; I_C = 100 мА; P_D = 125 мВт; h_{FE1} = 100...145; f_T > 4 ГГц$	SC81, MFPK	B-E-C
TV	2SC5599	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 9 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE1} = 80...160; f_T > 3.5 ГГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
TV	2SC5600	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 5.5 В; I_C = 15 мА; f_T = 5.5 ГГц$	SOT346, SC59	B-E-C
W3	BAT54A	PHIL	shd-2	$V_A < 30 В; I_F < 200 мА; V_{CE(sat)}(I_F=30 мА) < 500 мВ; C_D < 10 пФ; t_{95\%} < 5 нс$	SOT23, SOD23	K1-K2-A1, A2
W4	BAT54S	PHIL	shd-2	$V_A < 30 В; I_F < 200 мА; V_{CE(sat)}(I_F=30 мА) < 500 мВ; C_D < 10 пФ; t_{95\%} < 5 нс$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
TW	2SC5602	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 15 В; I_C = 35 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE1} = 60...120; f_T > 12 ГГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
TW	2SC5603	NEC	npn	$V_{CE(sat)} = 6 В; I_C = 15 мА; f_T = 13.5 ГГц$	SOT346, SC59	B-E-C
W1	BAT54C	PHIL	shd-2	$V_A < 30 В; I_F < 200 мА; V_{CE(sat)}(I_F=30 мА) < 500 мВ; C_D < 10 пФ; t_{95\%} < 5 нс$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
U1	BCX19	ALLEG	npn	$V_{CE(sat)} = 50 В; I_{C(sat)} < 100 мА; h_{FE1} = 100...600; V_{CE(sat)} < 0.62 В$	SOT23, SOD23	B-E-C
U1	BCX19	CDIL	npn	$V_{CE(sat)} = 45 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U1	BCX19	ZETEX	npn	$V_{CE(sat)} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE1} = 100...600; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U1	BCX19	MOT	npn	$V_{CE(sat)} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE1} = 100...600; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U1p	BCX19	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} = 45 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U11	BCX19	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} = 45 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U2	BCX20	ALLEG	npn	$V_{CE(sat)} = 30 В; I_{C(sat)} < 100 мА; h_{FE1} = 100...600; V_{CE(sat)} < 0.62 В$	SOT23, SOD23	B-E-C
U2	BCX20	ZETEX	npn	$V_{CE(sat)} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE1} = 100...600; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U2	BCX20	CDIL	npn	$V_{CE(sat)} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...600; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U2p	BCX20	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U2t	BCX20	PHIL	npn	$V_{CE(sat)} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U3	BSS64	FAIR	npn	$V_{CE(sat)} = 120 В; I_C = 200 мА; P_D = 350 мВт; h_{FE1} > 20; f_T > 60 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
U35	BSR19	CDIL	npn	$V_{CEB} = 160 В; I_C = 600 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} > 60; f_T = 300$	SOT23, SOD23	B-E-C
U35	BSR19	PHIL	npn	$V_{CEB} = 160 В; I_C = 600 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} > 60; f_T = 300$	SOT23, SOD23	B-E-C
U36	BSR19A	CDIL	npn	$V_{CEB} = 180 В; I_C = 600 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} > 80; f_T = 300$	SOT23, SOD23	B-E-C
U36	BSR19A	PHIL	npn	$V_{CEB} = 180 В; I_C = 600 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} > 80; f_T = 300$	SOT23, SOD23	B-E-C
U4	BCX19R	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE1} = 100...600; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	C-B-E
U4	BCX19R	PHIL	npn	$V_{CEB} = 45 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	C-B-E
U5	BCX20R	ZETEX	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE1} = 100...600; f_T > 200 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U5	BCX20R	PHIL	npn	$V_{CEB} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...600; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	C-B-E
U6	BSS64R	FAIR	npn	$V_{CEB} = 120 В; I_C = 200 мА; P_D = 350 мВт; h_{FE1} > 20; f_T > 60 МГц$	SOT23, SOD23	E-B-C
U7	BSR13	CDIL	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_C = 800 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U7	BSR13	SGS	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_C = 800 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U71	BSR13R	SGS	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_C = 800 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	E-B-C
U7p	BSR13	PHIL	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_C = 800 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U7L	BSR13	PHIL	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_C = 800 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U8	BSR14	CDIL	npn	$V_{CEB} = 75 В; I_C = 800 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...300; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U8	BSR14	SGS	npn	$V_{CEB} = 75 В; I_C = 800 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...300; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U81	BSR14R	SGS	npn	$V_{CEB} = 75 В; I_C = 800 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...300; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	C-B-E
U8p	BSR14	PHIL	npn	$V_{CEB} = 75 В; I_C = 800 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...300; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U8t	BSR14	PHIL	npn	$V_{CEB} = 75 В; I_C = 800 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...300; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U92	BSR17A	CDIL	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_C = 200 мА; P_D = 250 мВт; h_{FE1} = 100...300; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U92	BSR17A	FAIR	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_C = 200 мА; P_D = 350 мВт; h_{FE1} = 100...300; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U92p	BSR17A	PHIL	npn	$V_{CEB} = 60 В; I_C = 200 мА; P_D = 350 мВт; h_{FE1} = 100...300; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
U9p	BSR17	PHIL	npn	$V_{CEB} = 40 В; I_C = 200 мА; P_D = 425 мВт; h_{FE1} = 40; f_T > 300 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
UA	2SB852KA	ROHM	npn	$V_{CEB} = 40 В; I_C = 300 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE1} > 1000; f_T > 200 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
UB	2SB852KB	ROHM	npn	$V_{CEB} = 40 В; I_C = 300 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE1} > 5000; f_T > 200 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
UB	2SC5668	NEC	npn	$V_{CEB} = 15 В; I_C = 35 мА; P_D = 115 мВт; h_{FE1} = 50...100; f_T = 21 ГГц$	SC81, MFFPAK	B-E-C
UB	NE667M03	NEC	npn	$V_{CEB} = 15 В; I_C = 35 мА; P_D = 115 мВт; h_{FE1} = 50...100; f_T = 21 ГГц$	SC81, MFFPAK	B-E-C
UC	MSC2404-C	MOT	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
UF	8B801	SIEM	var	$V_R < 30 В; I_R < 50 мА; I_R < 0.02 мА; C_{28B} = 0.85...1.2 нФ; C_{1B}/C_{28B} = 7.8...9.5$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
UI	2SC4229	REN	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 20 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE1} = 50...180; f_T > 700 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
UI	2SC4259	REN	npn	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 20 мА; P_D = 100 мВт; h_{FE1} = 50...180; f_T > 700 МГц$	SOT323, SC70	A1-K2
UV	1SV315	SANYO	pin-2	$V_R > 50 В; I_R < 50 мА; V_{FE}(I_R = 50 мА) < 1 В; I_R < 0.1 мА$	SOT323, SC70	A1-K2-K1, A2
UV	1SV316	SANYO	pin-2	$V_R > 50 В; I_R < 50 мА; V_{FE}(I_R = 50 мА) < 1 В; I_R < 0.1 мА$	SOT23, SOD23	A1-K2-K1, A2
V04	VN45350T	SIL	nMOS	$V_{DS} = 450 В; I_D = 20 мА; P_D = 800 мВт; R_{DS(on)} < 350 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
V1	1SV160	TOSH	var	$V_R > 15 В; I_R(V_R = 4 В) < 0.1 мА; C_T = 14 нФ$	SOT346, SC59	n.c.-A-K
V1	DZ23C2V7	VISH	dz-2	$V_Z = 2.5...2.9 В; Z_{Tz}(I_Z = 5 мА) = 83 Ом$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V1	MRF959T1	MOT	npn	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 100 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE1} = 75...150; f_T = 9 ГГц$	SOT416, SC75A	B-E-C
V1	VN50300T	SIL	nMOS	$V_{DS} = 500 В; I_D = 22 мА; P_D = 350 мВт; g_{fs} = 140 мСм; R_{DS(on)} = 25 Ом$	SOT23, SOD23	G-S-D
V10	DZ23C6V2	VISH	dz-2	$V_Z = 5.8...6.6 В; Z_{Tz}(I_Z = 5 мА) = 10 Ом$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V11	DZ23C6V8	VISH	dz-2	$V_Z = 6.4...7.2 В; Z_{Tz}(I_Z = 5 мА) = 8 Ом$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V12	DZ23C7V5	VISH	dz-2	$V_Z = 7.0...7.9 В; Z_{Tz}(I_Z = 5 мА) = 7 Ом$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V13	DZ23C8V2	VISH	dz-2	$V_Z = 7.7...8.7 В; Z_{Tz}(I_Z = 5 мА) = 7 Ом$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V13	ZC932	ZETEX	var	$V_R < 12 В; C_D(V_R = 2.5 В) = 8.5...10.5 нФ; C_{2B}/C_{20B} < 3.1; Q > 200$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
V14	DZ23C9V1	VISH	dz-2	$V_Z = 8.5...9.6 В; Z_{Tz}(I_Z = 5 мА) = 10 Ом$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V14	ZC931	ZETEX	var	$V_R < 12 В; C_D(V_R = 2.5 В) = 6.5...7.8 нФ; C_{1B}/C_{4B} < 3.6; Q > 300$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
V15	ZC930	ZETEX	var	$V_R < 25 В; C_D(V_R = 2.5 В) = 4.3...5.5 нФ; C_{1B}/C_{4B} < 3.0; Q > 200$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
V15	ZDZ23C10	VISH	dz-2	$V_Z = 9.4...10 В; Z_{Tz}(I_Z = 5 мА) = 15 Ом$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V16	DZ23C11	VISH	dz-2	$V_Z = 10.4...11.8 В; Z_{Tz}(I_Z = 5 мА) = 20 Ом$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V16	ZC934	ZETEX	var	$V_R < 12 В; C_D(V_R = 2.5 В) = 40...65 нФ; C_{1B}/C_{4B} < 3.8; Q > 80$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
V17	DZ23C12	VISH	dz-2	$V_Z = 11.4...12 В; Z_{Tz}(I_Z = 5 мА) = 20 Ом$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V17	ZC933	ZETEX	var	$V_R < 12 В; C_D(V_R = 2.5 В) = 18...27 нФ; C_{1B}/C_{4B} < 3.5; Q > 150$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
V18	DZ23C13	VISH	dz-2	$V_Z = 12.4...14 В; Z_{Tz}(I_Z = 5 мА) = 25 Ом$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TSM
MFPK TSFP-3

VMT3
VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
V19	DZ23C15	WISH	dz-2	$V_2 = 13.8...15.0 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ мА}) = 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V1p	BFT25	PHIL	npn	$V_{CE0} = 8 \text{ В}; I_C = 6.5 \text{ мА}; P_D = 30 \text{ мВт}; h_{21} > 20; f_T = 2.3 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
V2	BF067	WIS	npn	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 65; f_T = 8 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
V2	DZ23C3V0	WISH	dz-2	$V_2 = 2.8...3.2 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ мА}) = 95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V2	VN0605T	SIL	nMOS	$V_{DS} = 60 \text{ В}; I_D = 180 \text{ мА}; P_D = 360 \text{ мВт}; g_m = 80 \text{ мСм}; R_{DS(on)} = 5 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
V20	DZ23C16	WISH	dz-2	$V_2 = 15.3...17.0 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ мА}) = 40 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V21	DZ23C18	WISH	dz-2	$V_2 = 16.8...19.0 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ мА}) = 50 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V22	DZ23C20	WISH	dz-2	$V_2 = 18.8...21.0 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ мА}) = 50 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V23	DZ23C22	WISH	dz-2	$V_2 = 20.8...23.0 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ мА}) = 55 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V24	DZ23C24	WISH	dz-2	$V_2 = 22.8...25.0 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ мА}) = 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V25	DZ23C27	WISH	dz-2	$V_2 = 25.8...28.0 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 2 \text{ мА}) = 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V25	PMBT3640	PHIL	npn	$V_{CE0} = 12 \text{ В}; I_C = 80 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} > 30...120; f_T > 500 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
V26	DZ23C30	WISH	dz-2	$V_2 = 28...32 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 2 \text{ мА}) = 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V27	DZ23C33	WISH	dz-2	$V_2 = 31...35 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 2 \text{ мА}) = 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V28	DZ23C36	WISH	dz-2	$V_2 = 34...38 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 2 \text{ мА}) = 90 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V29	DZ23C39	WISH	dz-2	$V_2 = 37...41 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 2 \text{ мА}) = 90 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V2p	BF067	PHIL	npn	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 60; f_T = 8 \text{ ГГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
V3	1S1225	TOSH	var-2	$V_R > 32 \text{ В}; I_R(V_R = 30 \text{ В}) < 0.05 \text{ мА}; C_{33} = 18.5...21 \text{ нФ}; C_{30} = 6.6...7.7 \text{ нФ}$	SOT346, SC59	A1-A2-K1, K2
V3	DZ23C3V3	WISH	dz-2	$V_2 = 3.1...3.5 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ мА}) = 95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V30	DZ23C43	WISH	dz-2	$V_2 = 40...46 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 2 \text{ мА}) = 100 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V30	DZ23C43	DIODS	dz-2	$V_2 = 40...46 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 2 \text{ мА}) = 100 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V31	DZ23CA7	WISH	dz-2	$V_2 = 44...50 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 2 \text{ мА}) = 100 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V31	DZ23CA7	DIODS	dz-2	$V_2 = 44...50 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 2 \text{ мА}) = 100 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V32	DZ23C51	WISH	dz-2	$V_2 = 48...54 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 2 \text{ мА}) = 100 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V32	DZ23C51	DIODS	dz-2	$V_2 = 48...54 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 2 \text{ мА}) = 100 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V4	1S1228	TOSH	var-2	$V_R > 15 \text{ В}; I_R(V_R = 15 \text{ В}) < 0.01 \text{ мА}; C_{33} = 28.5...32.5 \text{ нФ}; C_{30} = 11.7...13.7 \text{ нФ}$	SOT346, SC59	A1-A2-K1, K2
V4	DZ23C3V6	WISH	dz-2	$V_2 = 3.4...3.8 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ мА}) = 95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V5	1S1242	TOSH	var-2	$V_R > 30 \text{ В}; I_R(V_R = 28 \text{ В}) < 0.01 \text{ мА}; C_{13} = 36...42 \text{ нФ}; C_{28} = 2.43...3 \text{ нФ}$	SOT346, SC59	A1-A2-K1, K2
V5	DZ23C3V9	WISH	dz-2	$V_2 = 3.7...4.1 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ мА}) = 95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V6	DZ23CAV3	WISH	dz-2	$V_2 = 4.0...4.6 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ мА}) = 95 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V7	DZ23CAV7	WISH	dz-2	$V_2 = 4.4...5.0 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ мА}) = 78 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V8	DZ23C5V1	WISH	dz-2	$V_2 = 4.8...5.4 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ мА}) = 60 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
V9	DZ23C5V6	WISH	dz-2	$V_2 = 5.2...6.0 \text{ В}; Z_{T1}(I_2 = 5 \text{ мА}) = 40 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A1-A2-K1, K2
VA	2SC2776A	REN	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; h_{21} = 35...70; f_T = 320 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
VB	2SC2776B	REN	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; h_{21} = 60...120; f_T = 320 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
VB	MSC2295-B	MOT	npn	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 70...140; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
VC	2SC2776C	REN	npn	$V_{CE0} = 30 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; h_{21} = 100...200; f_T = 320 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	B-E-C
VC	MSC2295-C	MOT	npn	$V_{CE0} = 20 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 110...220; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	B-E-C
VO	YPO610T	SIL	pMOS	$V_{DS} = 60 \text{ В}; I_D = 120 \text{ мА}; P_D = 360 \text{ мВт}; g_m = 70 \text{ мСм}; R_{DS(on)} = 10 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	G-S-D
W01	PDTA143ET	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 30; 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	B-E-C
W01	PDTA143EU	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 30; 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
W02	PDTC143ET	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 30; 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	B-E-C
W02	PDTC143EU	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 30; 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
W05	PDTA124ET	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 60; 22 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	B-E-C
W05	PDTA124EU	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 60; 22 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
W06	PDTC124EU	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 60; 22 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
W06	PMSS3906	PHIL	npn	$V_{CE0} = 40 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 100...300; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23, SC70	B-E-C
W07	PDTA144ET	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 47 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	B-E-C
W07	PDTA144EU	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 47 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
W08	PDTC144ET	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 47 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23, SOD23	B-E-C
W08	PDTC144EU	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 80; 47 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C
W09	PDTC114EU	PHIL	Dnpnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 30; 10 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT323, SC70	B-E-C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3
VMD3



SOT416
SOT523

SOT323
SOT346

SOT23-3
SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
W10	CMPZDA2TV	CSI	dz-2	$V_{I(TZT-2\text{ MA})} > 25 \dots 29\text{ В}; I_{I(V_R)} < 0.05\text{ мкА}; Z_{T1(TZT-2.0\text{ MA})} < 80\text{ Ом}; I_{I2M} < 6.2\text{ MA}$	SOT23,SOD23	K2-K1-A2,A1
W11	CMPZDA30V	CSI	dz-2	$V_{I(TZT-2.0\text{ MA})} > 28 \dots 32\text{ В}; I_{I(V_R)} < 0.05\text{ мкА}; Z_{T1(TZT-2.0\text{ MA})} < 80\text{ Ом}; I_{I2M} < 5.6\text{ MA}$	SOT23,SOD23	K2-K1-A2,A1
W11	PDTA114TT	PHIL	Dpnp	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 200\text{ мВт}; h_{FE} > 200; R_T < 10\text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
W12	CMPZDA33V	CSI	dz-2	$V_{I(TZT-2.0\text{ MA})} > 31 \dots 35\text{ В}; I_{I(V_R)} < 0.05\text{ мкА}; Z_{T1(TZT-2.0\text{ MA})} < 80\text{ Ом}; I_{I2M} < 5.0\text{ MA}$	SOT23,SOD23	K2-K1-A2,A1
W12	PDTC114TT	PHIL	Dnpn	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 200\text{ мВт}; h_{FE} > 200; R_T < 10\text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
w13	BB207	PHIL	var-2	$V_R > 15\text{ В}; I_{I(V_R)} < 0.01\text{ мкА}; C_{1B} = 76 \dots 86\text{ нФ}; C_{7,5B} = 25.5 \dots 29.7\text{ нФ}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
W13	CMPZDA36V	CSI	dz-2	$V_2 > 36\text{ В}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	K2-K1-A2,A1
W14	CMPZDA39V	CSI	dz-2	$V_2 > 39\text{ В}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	K2-K1-A2,A1
W15	CMPZDA43V	CSI	dz-2	$V_2 > 43\text{ В}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	K2-K1-A2,A1
W16	CMPZDA47V	CSI	dz-2	$V_2 > 47\text{ В}(5\%); P_D < 350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	K2-K1-A2,A1
W16	PDTC114ET	PHIL	Dnpn	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 50\text{ mA}; P_D > 250\text{ мВт}; h_{FE} > 30; 10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
W17	PDTC124ET	PHIL	Dnpn	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 250\text{ мВт}; h_{FE} > 60; 22\text{ кОм}/22\text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
W18	PDTC143ZT	PHIL	Dnpn	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 250\text{ мВт}; h_{FE} > 100; 4.7\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
W19	PDTA143ZT	PHIL	Dpnp	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 250\text{ мВт}; h_{FE} > 100; 4.7\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
W1B	PMBT2222	PHIL	npn	$V_{CEB} > 60\text{ В}; I_C < 600\text{ mA}; P_D > 250\text{ мВт}; h_{FE} > 100 \dots 300; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
W1J	PMBT2369	PHIL	npn	$V_{CEB} > 40\text{ В}; I_C < 500\text{ mA}; P_D > 250\text{ мВт}; h_{FE} > 40 \dots 120$	SOT23,SOD23	B-E-C
W1P	PMBT2222A	PHIL	npn	$V_{CEB} > 75\text{ В}; I_C < 600\text{ mA}; P_D > 250\text{ мВт}; h_{FE} > 100 \dots 300; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
W1s	BFT92	SIEM	npn	$V_{CEB} > 20\text{ В}; I_C < 25\text{ mA}; P_D > 200\text{ мВт}; h_{FE} > 20; f_T > 5000\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
W1s	BFT92W	SIEM	npn	$V_{CEB} > 20\text{ В}; I_C < 25\text{ mA}; P_D > 200\text{ мВт}; h_{FE} > 15; f_T > 5000\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
W23	PDTA114TU	PHIL	Dpnp	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 200\text{ мВт}; h_{FE} > 200; R_T < 10\text{ кОм}$	SOT323,SC70	B-E-C
W24	PDTC114TU	PHIL	Dnpn	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 200\text{ мВт}; h_{FE} > 200; R_T < 10\text{ кОм}$	SOT323,SC70	B-E-C
W27	PDTC114YT	PHIL	Dnpn	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 200\text{ мВт}; h_{FE} > 100; 10\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
W29	PDTA114YT	PHIL	Dpnp	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 200\text{ мВт}; h_{FE} > 100; 10\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
W2F	PMBT2907A	PHIL	npn	$V_{CEB} > 60\text{ В}; I_C < 600\text{ mA}; P_D > 250\text{ мВт}; h_{FE} > 50; f_T > 200\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B-E-C
W3	BZX84-C2V4	PHIL	dz	$V_{I(TZT-5.0\text{ MA})} > 2.2 \dots 2.6\text{ В}; I_{I(V_R)} < 1.0\text{ В} < 50\text{ мкА}; Z_{T1(TZT-5.0\text{ MA})} < 100\text{ Ом}; I_{I2M} < 200\text{ MA}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
W30	PDTC114YU	PHIL	Dnpn	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 200\text{ мВт}; h_{FE} > 100; 10\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT323,SC70	B-E-C
W31	PDTA143XT	PHIL	Dpnp	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 250\text{ мВт}; h_{FE} > 50; 4.7\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
W32	PDTC143XT	PHIL	Dnpn	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 250\text{ мВт}; h_{FE} > 50; 4.7\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
W46	PDTA143XU	PHIL	Dpnp	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 250\text{ мВт}; h_{FE} > 50; 4.7\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT323,SC70	B-E-C
W47	PDTA143ZU	PHIL	Dpnp	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 250\text{ мВт}; h_{FE} > 100; 4.7\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT323,SC70	B-E-C
W5	BZX84-C3V0	PHIL	dz	$V_{I(TZT-5.0\text{ MA})} > 2.8 \dots 3.2\text{ В}; Z_{T1(TZT-5.0\text{ MA})} < 100\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
W52	S852TW	VISH	npn	$V_{CEB} > 12\text{ В}; I_C < 8\text{ mA}; P_D > 30\text{ мВт}; h_{FE} > 40 \dots 150; f_T > 5.2\text{ ГГц}$	SOT323,SC70	B-E-C
W53	PDTC143XU	PHIL	Dnpn	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 250\text{ мВт}; h_{FE} > 50; 4.7\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT323,SC70	B-E-C
W54	PDTC143ZU	PHIL	Dnpn	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 250\text{ мВт}; h_{FE} > 100; 4.7\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT323,SC70	B-E-C
W55	PDTA114YU	PHIL	Dpnp	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 100\text{ mA}; P_D > 200\text{ мВт}; h_{FE} > 100; 10\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT323,SC70	B-E-C
W6	BZX84C3V3	CSI	dz	$V_{I(TZT-5\text{ MA})} > 3.1 \dots 3.5\text{ В}; I_{I(V_R)} < 1.0\text{ В} < 5.0\text{ мкА}; Z_{T1(TZT-5\text{ MA})} < 95\text{ Ом}; I_{I2M} < 76\text{ MA}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
W6	BZX84-C3V3	PHIL	dz	$V_{I(TZT-5\text{ MA})} > 3.1 \dots 3.5\text{ В}; Z_{T1(TZT-5\text{ MA})} < 95\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
W7	BZX84C3V6	CSI	dz	$V_{I(TZT-5\text{ MA})} > 3.4 \dots 3.8\text{ В}; I_{I(V_R)} < 1.0\text{ В} < 5.0\text{ мкА}; Z_{T1(TZT-5\text{ MA})} < 90\text{ Ом}; I_{I2M} < 69\text{ MA}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
W7	BZX84-C3V6	PHIL	dz	$V_{I(TZT-5\text{ MA})} > 3.4 \dots 3.8\text{ В}; Z_{T1(TZT-5\text{ MA})} < 95\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
W74	BAW74	ZETEX	di-2	$V_R < 50\text{ В}; I_C < 150\text{ mA}; V_{I(I_F)} < 100\text{ mA} < 1.0\text{ В}; I_{I_0} < 0.1\text{ мкА}; C_D < 2.0\text{ нФ}; t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1-A2-K1,K2
W7Y	PDTB123YT	PHIL	Dpnp	$V_{CEB} > 50\text{ В}; I_C < 500\text{ mA}; P_D > 250\text{ мВт}; h_{FE} > 70; 2.2\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT23,SOD23	B-E-C
W8	BZX84C3V9	CSI	dz	$V_{I(TZT-5\text{ MA})} > 3.7 \dots 4.1\text{ В}; I_{I(V_R)} < 1.0\text{ В} < 3.0\text{ мкА}; Z_{T1(TZT-5\text{ MA})} < 90\text{ Ом}; I_{I2M} < 64\text{ MA}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
W8	BZX84-C3V9	PHIL	dz	$V_{I(TZT-5\text{ MA})} > 3.7 \dots 4.1\text{ В}; Z_{T1(TZT-5\text{ MA})} < 90\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
W9	BZX84C4V3	CSI	dz	$V_{I(TZT-5\text{ MA})} > 4.0 \dots 4.6\text{ В}; I_{I(V_R)} < 1.0\text{ В} < 3.0\text{ мкА}; Z_{T1(TZT-5\text{ MA})} < 90\text{ Ом}; I_{I2M} < 58\text{ MA}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K
W9	BZX84C4V3L1	MOT	dz	$V_{I(TZT-5\text{ MA})} > 4.0 \dots 4.6\text{ В}; Z_{T1(TZT-5\text{ MA})} < 90\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A-n.c.-K



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3
W9A	PLVA650A	PHIL	dz	$V_{CE(sat)}$: 250 мкА) < 4.8...5.2 В; $I_{CE(sat)}$: 0.8* $V_{CE(sat)}$ < 20 мА; $Z_{TE1}(f_{TE1})$: 250 мкА) < 700 Ом; I_{CE1} : 250 мА	SOT23,SOD23	A·n·c·K
W9B	PLVA653A	PHIL	dz	$V_{CE(sat)}$: 250 мкА) < 5.1...5.5 В; $I_{CE(sat)}$: 0.8* $V_{CE(sat)}$ < 5 мА; $Z_{TE1}(f_{TE1})$: 250 мкА) < 250 Ом; I_{CE1} : 250 мА	SOT23,SOD23	A·n·c·K
W9C	PLVA656A	PHIL	dz	$V_{CE(sat)}$: 250 мкА) < 5.4...5.8 В; $I_{CE(sat)}$: 0.8* $V_{CE(sat)}$ < 1 мА; $Z_{TE1}(f_{TE1})$: 250 мкА) < 100 Ом; I_{CE1} : 250 мА	SOT23,SOD23	A·n·c·K
W9D	PLVA659A	PHIL	dz	$V_{CE(sat)}$: 250 мкА) < 5.7...6.1 В; $I_{CE(sat)}$: 0.8* $V_{CE(sat)}$ < 500 нА; $Z_{TE1}(f_{TE1})$: 250 мкА) < 100 Ом; I_{CE1} : 250 мА	SOT23,SOD23	A·n·c·K
W9E	PLVA662A	PHIL	dz	$V_{CE(sat)}$: 250 мкА) < 6.0...6.4 В; $I_{CE(sat)}$: 0.8* $V_{CE(sat)}$ < 100 нА; $Z_{TE1}(f_{TE1})$: 250 мкА) < 100 Ом; I_{CE1} : 250 мА	SOT23,SOD23	A·n·c·K
W9F	PLVA665A	PHIL	dz	$V_{CE(sat)}$: 250 мкА) < 6.3...6.7 В; $I_{CE(sat)}$: 0.8* $V_{CE(sat)}$ < 50 нА; $Z_{TE1}(f_{TE1})$: 250 мкА) < 100 Ом; I_{CE1} : 250 мА	SOT23,SOD23	A·n·c·K
W9G	PLVA668A	PHIL	dz	$V_{CE(sat)}$: 250 мкА) < 6.6...7.0 В; $I_{CE(sat)}$: 0.8* $V_{CE(sat)}$ < 10 нА; $Z_{TE1}(f_{TE1})$: 250 мкА) < 100 Ом; I_{CE1} : 250 мА	SOT23,SOD23	A·n·c·K
WA	2SD1383KA	ROHM	nnp	$V_{CE(sat)}$: 40 В; I_{CE} : 300 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 1000; f_T : > 250 МГц	SOT346,SC59	B·E·C
WB	2SD1383KB	ROHM	nnp	$V_{CE(sat)}$: 40 В; I_{CE} : 300 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 5000; f_T : > 250 МГц	SOT346,SC59	B·E·C
WB-	2SC5700	REN	nnp	$V_{CE(sat)}$: 15 В; I_{CE} : 50 мА; P_D : 80 мВт; h_{FE1} : 100...170; f_T : > 10 ГГц	SC81,MFPK	B·E·C
WCs	BCR133	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 30; f_T : > 130 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
WCs	BCR133F	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 30; f_T : > 130 МГц	TSFP-3,VESM	B·E·C
WCs	BCR133T	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 30; f_T : > 130 МГц	SOT416,SC75A	B·E·C
WCs	BCR133W	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : > 30; f_T : > 130 МГц	SOT323,SC70	B·E·C
WDs	BCR141	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 50; f_T : > 130 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
WDs	BCR141F	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 50; f_T : > 130 МГц	TSFP-3,VESM	B·E·C
WDs	BCR141T	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 50; f_T : > 130 МГц	SOT416,SC75A	B·E·C
WDs	BCR141W	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : > 50; f_T : > 130 МГц	SOT323,SC70	B·E·C
WE1	BFS17W	TELEF	nnp	$V_{CE(sat)}$: 25 В; I_{CE} : 25 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : 20...150; f_T : > 1000 МГц	SOT323,SC70	B·E·C
WE2	BFS17AW	TELEF	nnp	$V_{CE(sat)}$: 25 В; I_{CE} : 25 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : 20...150; f_T : > 1000 МГц	SOT323,SC70	B·E·C
WEs	BCR148	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 70 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 100 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
WEs	BCR148F	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 70 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 100 МГц	TSFP-3,VESM	B·E·C
WEs	BCR148T	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 70 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 100 МГц	SOT416,SC75A	B·E·C
Wes	BCR148W	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 70 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 100 МГц	SOT323,SC70	B·E·C
WFs	BCR112	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 20; f_T : > 140 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
WFs	BCR112W	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : > 20; f_T : > 140 МГц	SOT323,SC70	B·E·C
WGs	BCR116	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 160 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
WGs	BCR116W	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 160 МГц	SOT323,SC70	B·E·C
WHs	BCR108	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 170 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
WHs	BCR108F	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 170 МГц	TSFP-3,VESM	B·E·C
WHs	BCR108T	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 170 МГц	SOT416,SC75A	B·E·C
WHs	BCR108W	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 170 МГц	SOT323,SC70	B·E·C
WIs	BCR158	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 200 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
WIs	BCR158F	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 70 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 100 МГц	TSFP-3,VESM	B·E·C
WIs	BCR158T	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 70 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 100 МГц	SOT416,SC75A	B·E·C
WIs	BCR158W	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 200 МГц	SOT323,SC70	B·E·C
WJs	BCR135	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 150 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
WJs	BCR135F	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 150 МГц	TSFP-3,VESM	B·E·C
WJs	BCR135T	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 150 МГц	SOT416,SC75A	B·E·C
WJs	BCR135W	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : > 70; f_T : > 150 МГц	SOT323,SC70	B·E·C
WK-	2SC5907	REN	nnp	$V_{CE(sat)}$: 15 В; I_{CE} : 80 мА; P_D : 80 мВт; h_{FE1} : 120...170; f_T : > 5 ГГц	SC81,MFPK	B·E·C
WKs	BCR119	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : 120...630; f_T : > 150 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
WKs	BCR119W	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : 120...630; f_T : > 150 МГц	SOT323,SC70	B·E·C
WL-	2SB1691	REN	pnp	$V_{CE(sat)}$: 60 В; I_{CE} : 1 А; P_D : 800 мВт; h_{FE1} : 200...500; f_T : > 310 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
WLS	BCR146	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 70 мА; P_D : 200 мВт; h_{FE1} : > 50; f_T : > 150 МГц	SOT23,SOD23	B·E·C
WLS	BCR146W	INF	Dnnp	$V_{CE(sat)}$: 50 В; I_{CE} : 70 мА; P_D : 250 мВт; h_{FE1} : > 50; f_T : > 150 МГц	SOT323,SC70	B·E·C

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
WMs	BCR183	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 30; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
WMs	BCR183F	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 30;$	TSFP-3,VE5M	B•E•C
WMs	BCR183T	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 30;$	SOT416,SC75A	B•E•C
WMs	BCR183W	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 30; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
WNs	BCR185	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
WNs	BCR185W	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
WO4	PMBS3904	PHIL	npn	$V_{CB0} = 60 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 100...300; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
WO6	PMBS3906	PHIL	npn	$V_{CB0} = 40 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 100...300; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
WOs	BCR191	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
WOs	BCR191W	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
WP2	BFR92A	TELEF	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 25 \text{ мА}; P_D = 273 \text{ мВт}; h_{21} > 40; f_T = 4500 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
WPs	BCR192	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
WPs	BCR192F	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T > 200 \text{ МГц}$	TSFP-3,VE5M	B•E•C
WPs	BCR192T	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT416,SC75A	B•E•C
WPs	BCR192W	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
WR	MSD602R	MOT	npn	$V_{CB0} = 25 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}$	SOT346,SC59	B•E•C
WR2	BFR93AW	TELEF	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200; f_T = 5500 \text{ МГц}$	SOT23,SC70	B•E•C
WRE	BFR280TW	TELEF	npn	$V_{CB0} = 10 \text{ В}; I_C = 10 \text{ мА}; P_D = 80 \text{ мВт}; h_{21} = 30...200; f_T = 7500 \text{ МГц}$	SOT23,SC70	B•E•C
WRF	BFR181TW	TELEF	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 175 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T = 8 \text{ ГГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
WRG	BFR182TW	TELEF	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 35 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200; f_T = 8000 \text{ МГц}$	SOT23,SC70	B•E•C
WRH	BFR183TW	TELEF	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 65 \text{ мА}; P_D = 450 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200; f_T = 8000 \text{ МГц}$	SOT23,SC70	B•E•C
WRs	BCR198	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 70 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T > 190 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
WRs	BCR198W	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 70 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T = 190 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
WSs	BCR169	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 120...630; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
WSs	BCR169W	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 120...630; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
WTs	BCR166	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T = 160 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
WTs	BCR166W	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T = 160 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
WU	BCR162T	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 20; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT416,SC75A	B•E•C
WUs	BCR162	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 20; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
WUs	BCR162F	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 20; f_T > 200 \text{ МГц}$	TSFP-3,VE5M	B•E•C
WUs	BCR162W	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 20; f_T > 200 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
WV2	BFQ67W	VIS	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 65; f_T = 8 \text{ ГГц}$	SOT23,SC70	B•E•C
WV3	BAT54A	PHIL	shd-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; V_{I(I_R = 30 \text{ мА})} < 500 \text{ мВ}; C_0 < 10 \text{ нФ}; t_{RR} < 5 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	K1•K2•A1•A2
WV4	BAT54S	PHIL	shd-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; V_{I(I_R = 30 \text{ мА})} < 500 \text{ мВ}; C_0 < 10 \text{ нФ}; t_{RR} < 5 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1•K2•K1•A2
WVs	BCR129	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 120...630; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
WW1	BAT54C	PHIL	shd-2	$V_R < 30 \text{ В}; I_R < 200 \text{ мА}; V_{I(I_R = 30 \text{ мА})} < 500 \text{ мВ}; C_0 < 10 \text{ нФ}; t_{RR} < 5 \text{ нс}$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1•K2
WW3	CMPZDA2V4	CSI	dz-2	$V_Z = 2.4 \text{ В}(5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2•A1
WW4	CMPZDA2V7	CSI	dz-2	$V_Z = 2.7 \text{ В}(5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2•A1
WW5	CMPZDA3V0	CSI	dz-2	$V_Z = 3.0 \text{ В}(5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2•A1
WW6	CMPZDA3V3	CSI	dz-2	$V_Z = 3.3 \text{ В}(5\%); P_D < 350 \text{ мВт}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2•A1
WW7	CMPZDA3V6	CSI	dz-2	$V_Z(I_{Z1} = 5.0 \text{ мА}) = 3.4...3.8 \text{ В}; I_{Z1}(V_Z = 1.0 \text{ В}) < 2.0 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_{Z1} = 5.0 \text{ мА}) < 95 \text{ Ом}; I_{ZM} = 45 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2•A1
WW8	CMPZDA3V9	CSI	dz-2	$V_Z(I_{Z1} = 5.0 \text{ мА}) = 3.7...4.1 \text{ В}; I_{Z1}(V_Z = 1.0 \text{ В}) < 2.0 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_{Z1} = 5.0 \text{ мА}) < 90 \text{ Ом}; I_{ZM} = 43 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2•A1
WW9	CMPZDA4V3	CSI	dz-2	$V_Z(I_{Z1} = 5.0 \text{ мА}) = 4.0...4.6 \text{ В}; I_{Z1}(V_Z = 1.0 \text{ В}) < 1.0 \text{ мкА}; Z_{T1}(I_{Z1} = 5.0 \text{ мА}) < 90 \text{ Ом}; I_{ZM} = 40 \text{ мА}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2•A1
WXs	BCR196	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 70 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
WXs	BCR196W	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 70 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T = 150 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
WZ	2SC5872	REN	npn	$V_{CB0} = 15 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 90...140; f_T = 10 \text{ ГГц}$	SC81,MFFPAK	B•E•C
WZs	BCR142	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
WZs	BCR142W	INF	Dnnp	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T = 150 \text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
X	2SB1051K	ROHM	npn	$V_{CB0} = 32 \text{ В}; I_C = 1000 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 390; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT346,SC59	B•E•C



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESP VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3
X1p	BFT93	PHIL	Dnnp	$V_{CE0} = 15 В; I_C = 35 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 20; f_T > 5500 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
X1s	BFT93	SIEM	Dnnp	$V_{CE0} = 15 В; I_C = 35 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 20; f_T > 5500 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
X2	BZX84-C30	ZETEX	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 2 мА) = 28.0...32.0 В; Z_{T1}(I_{Z1} = 2 мА) < 80 Ом$	SOT23, SOD23	А+н.с.-К
X2	BZX99-C13	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 50 мкА) = 12.35...13.65 В; P_D < 300 мВт$	SOT23, SOD23	А+н.с.-К
X3	BZX84-C33	ZETEX	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 2 мА) = 31.0...35.0 В; Z_{T1}(I_{Z1} = 2 мА) < 80 Ом$	SOT23, SOD23	А+н.с.-К
X3	BZX99-C15	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 50 мкА) = 14.25...15.75 В; P_D < 300 мВт$	SOT23, SOD23	А+н.с.-К
X4	BFT93R	SIEM	Dnnp	$V_{CE0} = 15 В; I_C = 35 мА; P_D = 300 мВт; h_{FE} > 20; f_T > 5500 МГц$	SOT23, SOD23	С+В+Е
X4	BZX84-C36	ZETEX	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 2 мА) = 33.0...38.0 В; Z_{T1}(I_{Z1} = 2 мА) < 90 Ом$	SOT23, SOD23	А+н.с.-К
X42	2SK1001	NEC	nFET	$V_{GS} = 22 В; I_D = 10 мА; P_D = 250 мВт; g_{fs} > 20 мСм; I_{OSS} = 10...50 мА$	SOT23, SOD23	Д+С+G
X43	2SK1001	NEC	FET	$V_{GS} = 22 В; I_D = 10 мА; P_D = 250 мВт; g_{fs} > 20 мСм; I_{OSS} = 10...50 мА$	SOT23, SOD23	Д+С+G
X5	MMBV409LT1	MOT	var	$V_D = 20 В; I_C = 200 мА; C_{J3} = 26...32 пФ; C_{J3}/C_{J6} = 1.5...1.9$	SOT23, SOD23	А+н.с.-К
X6	2SD1048X6	SANYO	nnp	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 700 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} = 200...400; f_T = 250 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
X6	BZX84-C43	ZETEX	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 2 мА) = 40.0...46.0 В; Z_{T1}(I_{Z1} = 2 мА) < 150 Ом$	SOT23, SOD23	А+н.с.-К
X7	2SD1048X7	SANYO	nnp	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 700 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} = 200...600; f_T = 250 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
X7	BZX84-C47	ZETEX	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 2 мА) = 44.0...50.0 В; Z_{T1}(I_{Z1} = 2 мА) < 170 Ом$	SOT23, SOD23	А+н.с.-К
X8	2SD1048X8	SANYO	nnp	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 700 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE} = 450...900; f_T = 250 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
X9	1SS398	TOSH	di-2	$V_{GS} = 400 В; I_C < 100 мА; V_{Z1}(I_{Z1} = 100 мА) < 1.3 В; I_{R1} < 1.0 мА$	SOT346, SC59	А1+К2+К1, А2
XA	BZX99-CAV7	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 50 мкА) = 4.47...4.94 В; P_D < 300 мВт$	SOT23, SOD23	А+н.с.-К
XA	RN1101	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 4.7/4.7 кОм$	SOT416, SC75A	В+Е+С
XA	RN1101F	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 4.7/4.7 кОм$	SOT490, SC89	В+Е+С
XA	RN1101FT	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 4.7/4.7 кОм$	TESM	В+Е+С
XA	RN1301	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 4.7 кОм/4.7 кОм$	SOT323, SC70	В+Е+С
XA	RN1401	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 200 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 4.7/4.7 кОм$	SOT346, SC59	В+Е+С
XAs	BCR503	INF	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE} > 40; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
XB	2SC4416	REN	nnp	$V_{CE0} = 25 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE} = 50...180; f_T > 3 ГГц$	SOT346, SC59	Е+В+С
XB	BZX99-CSV1	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 50 мкА) = 4.85...5.36 В; P_D < 300 мВт$	SOT23, SOD23	А+н.с.-К
XB	RN1102	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 10/10 кОм$	SOT416, SC75A	В+Е+С
XB	RN1102F	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 10/10 кОм$	SOT490, SC89	В+Е+С
XB	RN1102FT	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 10/10 кОм$	TESM	В+Е+С
XB	RN1302	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 10 кОм/10 кОм$	SOT323, SC70	В+Е+С
XB	RN1402	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 200 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 10/10 кОм$	SOT346, SC59	В+Е+С
XBs	BCR553	INF	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE} > 40; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
XC	BZX99-CSV6	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 50 мкА) = 5.32...5.88 В; P_D < 300 мВт$	SOT23, SOD23	А+н.с.-К
XC	RN1103	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 22/22 кОм$	SOT416, SC75A	В+Е+С
XC	RN1103F	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 22/22 кОм$	SOT490, SC89	В+Е+С
XC	RN1103FT	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 22/22 кОм$	TESM	В+Е+С
XC	RN1303	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 22 кОм/22 кОм$	SOT323, SC70	В+Е+С
XC	RN1403	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 200 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 22/22 кОм$	SOT346, SC59	В+Е+С
XCs	BCR533	INF	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE} > 70; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
XD	BZX99-C6V2	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 50 мкА) = 5.89...6.51 В; P_D < 300 мВт$	SOT23, SOD23	А+н.с.-К
XD	RN1104	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 47/47 кОм$	SOT416, SC75A	В+Е+С
XD	RN1104F	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 47/47 кОм$	SOT490, SC89	В+Е+С
XD	RN1104FT	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 47/47 кОм$	TESM	В+Е+С
XD	RN1304	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 47 кОм/47 кОм$	SOT323, SC70	В+Е+С
XD	RN1404	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 200 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 47/47 кОм$	SOT346, SC59	В+Е+С
XDs	BCR555	INF	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE} > 70; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	В+Е+С
XE	BZX99-C6V8	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1} = 50 мкА) = 6.46...7.14 В; P_D < 300 мВт$	SOT23, SOD23	А+н.с.-К
XE	RN1105	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 2.2/47 кОм$	SOT416, SC75A	В+Е+С
XE	RN1105F	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 2.2/47 кОм$	SOT490, SC89	В+Е+С
XE	RN1105FT	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 2.2/47 кОм$	TESM	В+Е+С
XE	RN1305	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 2.2 кОм/47 кОм$	SOT323, SC70	В+Е+С
XE	RN1405	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 200 МГц; R_{T1}/R_{T2} = 2.2/47 кОм$	SOT346, SC59	В+Е+С

SOT490 TESH
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
XF	2SC4464	REN	npn	$V_{CE0} = 15 В; I_C = 5 мА; P_D = 50 мВт; h_{FE1} = 40...250; f_T > 2.5 ГГц$	SOT323, SC70	B-E-C
XF	RN1106	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7/47 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
XF	RN1106F	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7/47 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
XF	RN1106FT	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7/47 кОм$	TESM	B-E-C
XF	RN1306	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
XF	RN1406	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 200 МГц; R_1/R_2 = 4.7/47 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
XF	BCR512	INF	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE1} > 60; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
XG	BCR523	INF	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE1} > 70; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
XH	RN1107	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 10/47 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
XH	RN1107F	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 10/47 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
XH	RN1107FT	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 10/47 кОм$	TESM	B-E-C
XH	RN1307	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
XH	RN1407	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 200 МГц; R_1/R_2 = 10/47 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
XHs	BCR573	INF	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE1} > 70; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
XI	RN1108	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 22/47 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
XI	RN1108F	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 22/47 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
XI	RN1108FT	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 22/47 кОм$	TESM	B-E-C
XI	RN1308	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
XI	RN1408	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 200 МГц; R_1/R_2 = 22/47 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
XJ	RN1109	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 47/22 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
XJ	RN1109F	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 47/22 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
XJ	RN1109FT	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 47/22 кОм$	TESM	B-E-C
XJ	RN1309	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
XJ	RN1409	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 200 МГц; R_1/R_2 = 47/22 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
XX	RN1110	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1 = 4.7 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
XX	RN1110F	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1 = 4.7 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
XX	RN1110FT	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1 = 4.7 кОм$	TESM	B-E-C
XX	RN1310	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1 = 4.7 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
XX	RN1410	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 200 МГц; R_1 = 4.7 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
XXs	BCR519	INF	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE1} = 120...630; f_T > 100 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
XL	BZX99-C2V4	PHIL	dz	$V_{Z(10V)} = 50 мкА) \cdot 2.28...2.52 В; P_D = 300 мВт$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
XLs	BCR569	INF	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE1} = 120...630; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
XM	2SC4591	REN	npn	$V_{CE0} = 15 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE1} = 40...250; f_T > 6.5 ГГц$	SOT346, SC59	B-E-C
XM	2SC4593	REN	npn	$V_{CE0} = 15 В; I_C = 50 мА; P_D = 100 мВт; h_{FE1} = 40...250; f_T > 6.5 ГГц$	SOT323, SC70	B-E-C
XM	BZX99-C2V7	PHIL	dz	$V_{Z(10V)} = 50 мкА) \cdot 2.57...2.84 В; P_D = 300 мВт$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
XM	RN1111	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1 = 10 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
XM	RN1111F	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1 = 10 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
XM	RN1111FT	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1 = 10 кОм$	TESM	B-E-C
XM	RN1311	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1 = 10 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
XM	RN1411	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 200 МГц; R_1 = 10 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
XMs	BCR583	INF	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 330 мВт; h_{FE1} > 70; f_T > 150 МГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
XN	BZX99-C3V0	PHIL	dz	$V_{Z(10V)} = 50 мкА) \cdot 2.85...3.15 В; P_D = 300 мВт$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
XN	RN1112	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1 = 22 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
XN	RN1112F	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1 = 22 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
XN	RN1112FT	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1 = 22 кОм$	TESM	B-E-C
XN	RN1312	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1 = 22 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
XN	RN1412	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T > 200 МГц; R_1 = 22 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
XP	BZX99-C3V3	PHIL	dz	$V_{Z(10V)} = 50 мкА) \cdot 3.14...3.47 В; P_D = 300 мВт$	SOT23, SOD23	A-n.c.-K
XP	MMD3000T1	MOT	di	$V_R < 30 В; I_R < 200 мА; V_{F(I_F = 10 мА)} < 0.95 В; C_D < 2 пФ; t_{RR} < 3 нс$	SOT346, SC59	n.c.-A-K
XP	RN1113	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1 = 47 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
XP	RN1113F	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1 = 47 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
XP	RN1113FT	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 150 мА; P_D = 100 мВт; f_T > 250 МГц; R_1 = 47 кОм$	TESM	B-E-C



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TESH VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
XP	RN1313	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} = 47 \text{ К/м}^2$	SOT323, SC70	В•Е•С
XP	RN1413	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta} = 47 \text{ К/м}^2$	SOT346, SC59	В•Е•С
XQ	2PD602AQ	PHIL	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE} = 85 \dots 170; f_T = 140 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	В•Е•С
XQ	MMBD3005T1	MOT	di-2	$V_B < 30 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 10 \text{ мА}) < 0.95 \text{ В}$	SOT346, SC59	K1-K2-A1, A2
XQ	RN1114	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 1 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT416, SC75A	В•Е•С
XQ	RN1114F	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 1 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT490, SC89	В•Е•С
XQ	RN1114FT	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 1 / 10 \text{ К/м}^2$	TESM	В•Е•С
XQ	RN1314	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 1 \text{ К/м}^2 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT323, SC70	В•Е•С
XQ	RN1414	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 1 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT346, SC59	В•Е•С
XQ	RN2114FT	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 1 \text{ К/м}^2 / 10 \text{ К/м}^2$	TESM	В•Е•С
XR	2PD602AR	PHIL	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE} = 120 \dots 240; f_T = 160 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	В•Е•С
XR	BZK99-C3V6	PHIL	dz	$V_{Z}(I_{TZ} = 50 \text{ мкА}) = 3.42 \dots 3.78 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A•n.c. • K
XS	2PD602AS	PHIL	npn	$V_{CE0} = 60 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{FE} = 170 \dots 340; f_T = 180 \text{ МГц}$	SOT346, SC59	В•Е•С
XS	BZK99-C3V9	PHIL	dz	$V_{Z}(I_{TZ} = 50 \text{ мкА}) = 3.71 \dots 4.1 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A•n.c. • K
XS	MMBD3010	MOT	di-2	$V_B < 30 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_{CE}(I_C = 10 \text{ мА}) < 0.95 \text{ В}; C_D < 2 \text{ пФ}; t_{\text{рег}} < 3 \text{ нс}$	SOT346, SC59	A1-A2-K1, K2
XS	RN1115	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 2.2 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT416, SC75A	В•Е•С
XS	RN1115F	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 2.2 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT490, SC89	В•Е•С
XS	RN1115FT	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 2.2 / 10 \text{ К/м}^2$	TESM	В•Е•С
XS	RN1315	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 2.2 \text{ К/м}^2 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT323, SC70	В•Е•С
XS	RN1415	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 2.2 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT346, SC59	В•Е•С
XS	RN2115FT	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 2.2 \text{ К/м}^2 / 10 \text{ К/м}^2$	TESM	В•Е•С
XT	2SC4674	REN	npn	$V_{CE0} = 12 \text{ В}; I_C = 8 \text{ мА}; P_D = 50 \text{ мВт}; h_{FE} = 50 \dots 250; f_T = 4 \text{ ГГц}$	SOT323, SC70	В•Е•С
XT	BZK99-C4V3	PHIL	dz	$V_{Z}(I_{TZ} = 50 \text{ мкА}) = 4.09 \dots 4.52 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A•n.c. • K
XT	RN1116	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 4.7 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT416, SC75A	В•Е•С
XT	RN1116F	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 4.7 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT490, SC89	В•Е•С
XT	RN1116FT	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 4.7 / 10 \text{ К/м}^2$	TESM	В•Е•С
XT	RN1316	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 4.7 \text{ К/м}^2 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT323, SC70	В•Е•С
XT	RN1416	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 4.7 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT346, SC59	В•Е•С
XT	RN2116FT	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 4.7 \text{ К/м}^2 / 10 \text{ К/м}^2$	TESM	В•Е•С
XU	2SC4680	REN	npn	$V_{CE0} = 12 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE} > 100$	SOT346, SC59	В•Е•С
XU	BZK99-C7V5	PHIL	dz	$V_{Z}(I_{TZ} = 50 \text{ мкА}) = 7.13 \dots 7.88 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A•n.c. • K
XU	RN1117	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 10 / 4.7 \text{ К/м}^2$	SOT416, SC75A	В•Е•С
XU	RN1117F	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 10 / 4.7 \text{ К/м}^2$	SOT490, SC89	В•Е•С
XU	RN1117FT	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 10 / 4.7 \text{ К/м}^2$	TESM	В•Е•С
XU	RN1317	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 10 \text{ К/м}^2 / 4.7 \text{ К/м}^2$	SOT323, SC70	В•Е•С
XU	RN1417	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 10 / 4.7 \text{ К/м}^2$	SOT346, SC59	В•Е•С
XU	RN2117FT	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 10 \text{ К/м}^2 / 4.7 \text{ К/м}^2$	TESM	В•Е•С
XU-	2SC4680	REN	npn	$V_{CE0} = 12 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{FE} > 100$	SOT23, SOD23	В•Е•С
XUs	BCR562	INF	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE} > 60; f_T = 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
XV	BZK99-C8V2	PHIL	dz	$V_{Z}(I_{TZ} = 50 \text{ мкА}) = 7.79 \dots 8.61 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A•n.c. • K
XVs	BCR521	INF	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE} > 20; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
XW	BZK99-C9V1	PHIL	dz	$V_{Z}(I_{TZ} = 50 \text{ мкА}) = 8.65 \dots 9.56 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A•n.c. • K
XW	RN1118	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 47 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT416, SC75A	В•Е•С
XW	RN1118F	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 47 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT490, SC89	В•Е•С
XW	RN1118FT	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 47 / 10 \text{ К/м}^2$	TESM	В•Е•С
XW	RN1318	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 47 \text{ К/м}^2 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT323, SC70	В•Е•С
XW	RN1418	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 47 / 10 \text{ К/м}^2$	SOT346, SC59	В•Е•С
XW	RN2118FT	TOSH	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta} / R_{\theta} = 47 \text{ К/м}^2 / 10 \text{ К/м}^2$	TESM	В•Е•С
XWs	BCR505	INF	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE} > 70; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
XX	BZK99-C10	PHIL	dz	$V_{Z}(I_{TZ} = 50 \text{ мкА}) = 9.5 \dots 10.5 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A•n.c. • K
XXs	BCR571	INF	Dnnp	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 330 \text{ мВт}; h_{FE} > 20; f_T = 150 \text{ МГц}$	SOT23, SOD23	В•Е•С
XY	BZK99-C11	PHIL	dz	$V_{Z}(I_{TZ} = 50 \text{ мкА}) = 10.45 \dots 11.55 \text{ В}; P_D < 300 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A•n.c. • K

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	PHL	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
XZ	BZX99-C12	PHIL	dz	$V_{Z(TZ)} = 50 \text{ мкА}$; $11.4...12.6 \text{ В}$; $P_D < 300 \text{ мВт}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•K
XZ-	2SC5628	REN	npn	$V_{CEB} = 15 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ мА}$; $P_D = 80 \text{ мВт}$; $I_{B2} = 80...160$; $f_T > 6 \text{ ГГц}$	SC81, MFFPAK	B•E•C
XZ-	2SC5629	REN	npn	$V_{CEB} = 15 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ мА}$; $P_D = 80 \text{ мВт}$; $I_{B2} = 80...160$; $f_T > 2 \text{ ГГц}$	SOT416, SOT57A	B•E•C
Y1	BZX84C11	ALLEG	dz	$V_{Z(TZ)} = 5 \text{ мА}$; $10.4...11.6 \text{ В}$; $I_1(V_F = 8.0 \text{ В}) < 0.1 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 5 \text{ мА}) < 20 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•K
Y1	BZX84C11	PHIL	dz	$V_{Z(TZ)} = 5 \text{ мА}$; $10.4...11.6 \text{ В}$; $I_1(V_F = 8.0 \text{ В}) < 0.1 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 5 \text{ мА}) < 20 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 23 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•K
Y1	BZX84C11	VISH	dz	$V_{Z(TZ)} = 5 \text{ мА}$; $10.4...11.6 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 5 \text{ мА}) < 20 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•K
Y1	BZX84C11LT1	MOT	dz	$V_{Z(TZ)} = 5 \text{ мА}$; $10.4...11.6 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 5 \text{ мА}) < 20 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•K
Y10	BZX84C27	ALLEG	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $25.1...28.9 \text{ В}$; $I_1(V_F = 21.0 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•K
Y10	BZX84C27	CSI	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $25.1...28.9 \text{ В}$; $I_1(V_F = 18.9 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 9 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•K
Y10	BZX84C27	PHIL	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $25.1...28.9 \text{ В}$; $I_1(V_F = 18.9 \text{ В}) < 50 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2.0 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•K
Y10	BZX84C27	VISH	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $25.1...28.9 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•K
Y11	BZX84C30	ALLEG	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $28.0...32.0 \text{ В}$; $I_1(V_F = 18.9 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•K
Y11	BZX84C30	CSI	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $28.0...32.0 \text{ В}$; $I_1(V_F = 21.0 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 8 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y11	BZX84C30	PHIL	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $28.0...32.0 \text{ В}$; $I_1(V_F = 21.0 \text{ В}) < 50 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2.0 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y11	BZX84C30	VISH	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $28.0...32.0 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y11	BZX84C30LT1	MOT	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $28.0...32.0 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y12	BZX84C33	ALLEG	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $31.0...35.0 \text{ В}$; $I_1(V_F = 23.1 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y12	BZX84C33	CSI	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $31.0...35.0 \text{ В}$; $I_1(V_F = 23.1 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 7 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y12	BZX84C33	PHIL	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $31.0...35.0 \text{ В}$; $I_1(V_F = 23.1 \text{ В}) < 50 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2.0 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y12	BZX84C33	VISH	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $31.0...35.0 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y12	BZX84C33LT1	MOT	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $31.0...35.0 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y13	BZX84C36	PHIL	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $34.0...38.0 \text{ В}$; $I_1(V_F = 25.2 \text{ В}) < 50 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2.0 \text{ мА}) < 90 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y13	BZX84C36	VISH	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $33.0...38.0 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 90 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y13	BZX84C36LT1	MOT	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $33.0...38.0 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 90 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y14	BZX84C39	PHIL	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $37.0...41.0 \text{ В}$; $I_1(V_F = 27.3 \text{ В}) < 50 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2.0 \text{ мА}) < 75 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 250 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y14	BZX84C39	VISH	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $36.0...41.0 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 130 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y14	BZX84C39LT1	MOT	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $36.0...41.0 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 130 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y15	BZX84C43	PHIL	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $40.0...46.0 \text{ В}$; $I_1(V_F = 30.1 \text{ В}) < 50 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2.0 \text{ мА}) < 150 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y15	BZX84C43	VISH	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $40.0...46.0 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 150 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y15	BZX84C43LT1	MOT	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $40.0...46.0 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 150 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y16	BZX84C47	PHIL	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $44.0...50.0 \text{ В}$; $I_1(V_F = 32.9 \text{ В}) < 50 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2.0 \text{ мА}) < 170 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y16	BZX84C47	VISH	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $44.0...50.0 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 170 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y16	BZX84C47LT1	MOT	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $44.0...50.0 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 170 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y17	BZX84C51	PHIL	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $48.0...54.0 \text{ В}$; $I_1(V_F = 35.7 \text{ В}) < 50 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2.0 \text{ мА}) < 180 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y17	BZX84C51	VISH	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $48.0...54.0 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 180 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y17	BZX84C51LT1	MOT	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $48.0...54.0 \text{ В}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2 \text{ мА}) < 180 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y18	BZX84C56	PHIL	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $52.0...60.0 \text{ В}$; $I_1(V_F = 39.2 \text{ В}) < 50 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2.0 \text{ мА}) < 200 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y18	BZX84C56LT1	MOT	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $52.0...60.0 \text{ В}$; $I_1(V_F = 39.2 \text{ В}) < 50 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2.0 \text{ мА}) < 200 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y19	BZX84C62	PHIL	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $58.0...66.0 \text{ В}$; $I_1(V_F = 43.4 \text{ В}) < 50 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2.0 \text{ мА}) < 215 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K
Y19	BZX84C62LT1	MOT	dz	$V_{Z(TZ)} = 2 \text{ мА}$; $58.0...66.0 \text{ В}$; $I_1(V_F = 43.4 \text{ В}) < 50 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{T1} = 2.0 \text{ мА}) < 215 \text{ Ом}$; $I_{ZM} = 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~K



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490
MFPK

TESM **VMT3**
TSFP-3 **VMD3**

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
Y1p	BZX84C11	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 10.4...11.6 В; $I_L(V_R=8.0 \text{ В}) < 100 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 20 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y1t	BZX84C11	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 10.4...11.6 В; $I_L(V_R=8.0 \text{ В}) < 100 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 20 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y2	BZX84C12	ALLEG	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 11.4...12.7 В; $I_L(V_R=8.0 \text{ В}) < 0.1 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 25 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y2	BZX84C12	CSI	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 11.4...12.7 В; $I_L(V_R=8.0 \text{ В}) < 0.1 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 25 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 21 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y2	BZX84C12	VISH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 11.4...12.7 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 25 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y2	BZX84C12LT1	MOT	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 11.4...12.7 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 25 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y20	BZX84C68	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=2 \text{ mA})$: 64.60...72.0 В; $I_L(V_R=47.6 \text{ В}) < 50 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=2.0 \text{ мА}) < 240 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y21	BZX84C75	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=2 \text{ mA})$: 70.0...79.0 В; $I_L(V_R=52.5 \text{ В}) < 50 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=2.0 \text{ мА}) < 255 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y2p	BZX84C12	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 11.4...12.7 В; $I_L(V_R=8.0 \text{ В}) < 100 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 25 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y2t	BZX84C12	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 11.4...12.7 В; $I_L(V_R=8.0 \text{ В}) < 100 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 25 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y3	BZX84C13	ALLEG	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 12.4...14.1 В; $I_L(V_R=8.0 \text{ В}) < 0.1 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y3	BZX84C13	CSI	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 12.4...14.1 В; $I_L(V_R=8.0 \text{ В}) < 0.1 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 30 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 19 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y3	BZX84C13	VISH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 12.4...14.1 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y3	BZX84C13LT1	MOT	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 12.4...14.1 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y36	BZX84-C13V6	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 12.4...14.1 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y3p	BZX84C13	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 12.4...14.1 В; $I_L(V_R=8.0 \text{ В}) < 100 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 30 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y3t	BZX84C13	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 12.4...14.1 В; $I_L(V_R=8.0 \text{ В}) < 100 \text{ нА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 30 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y4	BZX84C15	ALLEG	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 13.8...15.6 В; $I_L(V_R=10.5 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y4	BZX84C15	CSI	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 13.8...15.6 В; $I_L(V_R=10.5 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 30 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 17 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y4	BZX84C15	VISH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 13.8...15.6 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y4	BZX84C15LT1	MOT	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 13.8...15.6 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 30 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y4p	BZX84C15	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 13.8...15.6 В; $I_L(V_R=10.5 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 30 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y4t	BZX84C15	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 13.8...15.6 В; $I_L(V_R=10.5 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 30 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y5	BZX84C16	ALLEG	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 15.3...17.1 В; $I_L(V_R=11.2 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 40 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y5	BZX84C16	CSI	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 15.3...17.1 В; $I_L(V_R=11.2 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 40 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 16 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y5	BZX84C16	VISH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 15.3...17.1 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5 \text{ мА}) < 40 \text{ Ом}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y50	BZX84A2V4	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 2.37...2.43 В; $I_L(V_R=1.0 \text{ В}) < 50 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 100 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y51	BZX84A2V7	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 2.67...2.73 В; $I_L(V_R=1.0 \text{ В}) < 20 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 100 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y52	BZX84A3V0	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 2.97...3.03 В; $I_L(V_R=1.0 \text{ В}) < 10 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 95 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y53	BZX84A3V3	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 3.26...3.34 В; $I_L(V_R=1.0 \text{ В}) < 5 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 95 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y54	BZX84A3V6	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 3.56...3.64 В; $I_L(V_R=1.0 \text{ В}) < 5 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 90 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y55	BZX84A3V9	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 3.86...3.94 В; $I_L(V_R=1.0 \text{ В}) < 3 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 90 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y56	BZX84A4V3	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 4.25...4.35 В; $I_L(V_R=1.0 \text{ В}) < 3 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 90 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y57	BZX84A4V7	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 4.65...4.75 В; $I_L(V_R=2.0 \text{ В}) < 3 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 80 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К
Y58	BZX84A5V1	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5 \text{ mA})$: 5.04...5.16 В; $I_L(V_R=2.0 \text{ В}) < 2 \text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0 \text{ мА}) < 60 \text{ Ом}$; $I_{ZM} < 200 \text{ мА}$	SOT23, SOD23	А•н.с•К

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
Y59	BZX84A5V6	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=5.54\dots 5.66 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=2.0 \text{ В}) < 1 \text{ мкА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 40 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y5p	BZX84C16	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=15.3\dots 17.1 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=11.2 \text{ В}) < 50 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 40 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y5t	BZX84C16	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=15.3\dots 17.1 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=11.2 \text{ В}) < 50 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 40 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y6	BZX84C18	ALLEG	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=16.8\dots 19.1 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=12.6 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5 \text{ mA}) < 45 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y6	BZX84C18	CSI	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=16.8\dots 19.1 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=12.6 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5 \text{ mA}) < 45 \text{ Ом}; I_{z2M}=14 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y6	BZX84C18	VISH	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=16.8\dots 19.1 \text{ В}; Z_{Tz}(I_{zT}=5 \text{ mA}) < 45 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y6	BZX84C18LT1	MOT	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=16.8\dots 19.1 \text{ В}; Z_{Tz}(I_{zT}=5 \text{ mA}) < 45 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y60	BZX84A6V2	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=6.13\dots 6.27 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=4.0 \text{ В}) < 3 \text{ мкА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 10 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y61	BZX84A6V8	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=6.73\dots 6.87 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=4.0 \text{ В}) < 2 \text{ мкА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y62	BZX84A7V5	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=7.42\dots 7.58 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=5.0 \text{ В}) < 1 \text{ мкА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y63	BZX84A8V2	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=8.11\dots 8.29 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=5.0 \text{ В}) < 700 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y64	BZX84A9V1	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=9.00\dots 9.20 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=6.0 \text{ В}) < 500 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y65	BZX84A10	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=9.9\dots 10.1; I_{z}(V_{z}=7.0 \text{ В}) < 200 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 20 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y66	BZX84A11	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=10.8\dots 11.1 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=8.0 \text{ В}) < 100 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 20 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y67	BZX84A12	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=11.88\dots 12.12 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=8.0 \text{ В}) < 100 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 25 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y68	BZX84A13	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=12.87\dots 13.13 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=8.0 \text{ В}) < 100 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 30 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y69	BZX84A15	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=14.9\dots 15.2 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=10.5 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 30 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y6p	BZX84C18	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=16.8\dots 19.1 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=12.6 \text{ В}) < 50 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 45 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y6t	BZX84C18	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=16.8\dots 19.1 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=12.6 \text{ В}) < 50 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 45 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y7	BZX84C20	ALLEG	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=18.8\dots 21.2 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=14.0 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5 \text{ mA}) < 55 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y7	BZX84C20	CSI	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=18.8\dots 21.2 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=14.0 \text{ В}) < 0.05 \text{ мкА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5 \text{ mA}) < 55 \text{ Ом}; I_{z2M}=12 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y7	BZX84C20	VISH	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=18.8\dots 21.2 \text{ В}; Z_{Tz}(I_{zT}=5 \text{ mA}) < 55 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Y7	BZX84C20LT1	MOT	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=18.8\dots 21.2 \text{ В}; Z_{Tz}(I_{zT}=5 \text{ mA}) < 55 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Y70	BZX84A16	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=15.84\dots 16.16 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=11.2 \text{ В}) < 50 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 40 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Y71	BZX84A18	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=17.8\dots 18.2 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=12.6 \text{ В}) < 50 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 45 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Y72	BZX84A20	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=19.8\dots 20.2 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=14.0 \text{ В}) < 50 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 55 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Y73	BZX84A22	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=21.8\dots 22.2 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=15.4 \text{ В}) < 50 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 55 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Y74	BZX84A24	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=5 \text{ mA})=23.8\dots 24.2 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=16.8 \text{ В}) < 50 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=5.0 \text{ mA}) < 30 \text{ Ом}; I_{z2M}=250 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Y75	BZX84A27	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=2 \text{ mA})=26.7\dots 27.3 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=18.9 \text{ В}) < 50 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=2.0 \text{ mA}) < 80 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Y76	BZX84A30	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=2 \text{ mA})=29.7\dots 30.3 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=21.0 \text{ В}) < 50 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=2.0 \text{ mA}) < 80 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Y77	BZX84A33	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=2 \text{ mA})=32.7\dots 33.3 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=23.1 \text{ В}) < 50 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=2.0 \text{ mA}) < 80 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Y78	BZX84A36	PHIL	dz	$V_{z}(I_{zT}=2 \text{ mA})=35.6\dots 36.4 \text{ В}; I_{z}(V_{z}=25.2 \text{ В}) < 50 \text{ нА}; Z_{Tz}(I_{zT}=2.0 \text{ mA}) < 90 \text{ Ом}; I_{z2M}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K



SOT23-3 **SOT323** **SOT416**
SOD23-3 **SOT346** **SOT523**



SOT490 **TESM** **VMT3**
MFPK **TSFP-3** **VMD3**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
Y79	BZX84A39	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=2\text{ mA})=38.6\dots39.4\text{ В}; I_L(V_R=27.3\text{ В}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{Z1}=2.0\text{ mA}) < 75\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y7p	BZX84C20	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5\text{ mA})=18.8\dots21.2\text{ В}; I_L(V_R=14.0\text{ В}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{Z1}=5.0\text{ mA}) < 55\text{ Ом}; I_{ZM}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y7l	BZX84C20	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5\text{ mA})=18.8\dots21.2\text{ В}; I_L(V_R=14.0\text{ В}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{Z1}=5.0\text{ mA}) < 55\text{ Ом}; I_{ZM}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y8	BZX84C22	ALLEG	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5\text{ mA})=20.8\dots23.3\text{ В}; I_L(V_R=15.4\text{ В}) < 0.05\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{Z1}=5\text{ mA}) < 55\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y8	BZX84C22	CSI	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5\text{ mA})=20.8\dots23.3\text{ В}; I_L(V_R=15.4\text{ В}) < 0.05\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{Z1}=5\text{ mA}) < 55\text{ Ом}; I_{ZM} < 11\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y8	BZX84C22	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5\text{ mA})=20.8\dots23.3\text{ В}; Z_{T1}(I_{Z1}=5\text{ mA}) < 55\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y8	BZX84C22LT1	MOT	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5\text{ mA})=20.8\dots23.3\text{ В}; Z_{T1}(I_{Z1}=5\text{ mA}) < 55\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y80	BZX84A43	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=2\text{ mA})=42.6\dots43.4\text{ В}; I_L(V_R=30.1\text{ В}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{Z1}=2.0\text{ mA}) < 150\text{ Ом}; I_{ZM}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y81	BZX84A47	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=2\text{ mA})=46.5\dots47.5\text{ В}; I_L(V_R=32.9\text{ В}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{Z1}=2.0\text{ mA}) < 170\text{ Ом}; I_{ZM}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y82	BZX84A51	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=2\text{ mA})=50.5\dots51.5\text{ В}; I_L(V_R=35.7\text{ В}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{Z1}=2.0\text{ mA}) < 180\text{ Ом}; I_{ZM}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y83	BZX84A56	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=2\text{ mA})=55.4\dots56.6\text{ В}; I_L(V_R=39.2\text{ В}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{Z1}=2.0\text{ mA}) < 200\text{ Ом}; I_{ZM}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y84	BZX84A62	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=2\text{ mA})=61.4\dots62.6\text{ В}; I_L(V_R=43.4\text{ В}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{Z1}=2.0\text{ mA}) < 215\text{ Ом}; I_{ZM}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y85	BZX84A68	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=2\text{ mA})=67.3\dots68.7\text{ В}; I_L(V_R=47.6\text{ В}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{Z1}=2.0\text{ mA}) < 240\text{ Ом}; I_{ZM}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y86	BZX84A75	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=2\text{ mA})=74.3\dots75.7\text{ В}; I_L(V_R=52.5\text{ В}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{Z1}=2.0\text{ mA}) < 255\text{ Ом}; I_{ZM}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y8p	BZX84C22	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5\text{ mA})=20.8\dots23.3\text{ В}; I_L(V_R=15.4\text{ В}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{Z1}=5.0\text{ mA}) < 55\text{ Ом}; I_{ZM}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y8t	BZX84C22	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5\text{ mA})=20.8\dots23.3\text{ В}; I_L(V_R=15.4\text{ В}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{Z1}=5.0\text{ mA}) < 55\text{ Ом}; I_{ZM}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y9	BZX84C24	ALLEG	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5\text{ mA})=22.8\dots25.6\text{ В}; I_L(V_R=16.8\text{ В}) < 0.05\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{Z1}=5\text{ mA}) < 70\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y9	BZX84C24	CSI	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5\text{ mA})=22.8\dots25.6\text{ В}; I_L(V_R=16.8\text{ В}) < 0.05\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{Z1}=5\text{ mA}) < 70\text{ Ом}; I_{ZM} < 10\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y9	BZX84C24	VISH	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5\text{ mA})=22.8\dots25.6\text{ В}; Z_{T1}(I_{Z1}=5\text{ mA}) < 70\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y9	BZX84C24LT1	MOT	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5\text{ mA})=22.8\dots25.6\text{ В}; Z_{T1}(I_{Z1}=5\text{ mA}) < 70\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y9p	BZX84C24	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5\text{ mA})=22.8\dots25.6\text{ В}; I_L(V_R=16.8\text{ В}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{Z1}=5.0\text{ mA}) < 30\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
Y9t	BZX84C24	PHIL	dz	$V_{Z1}(I_{Z1}=5\text{ mA})=22.8\dots25.6\text{ В}; I_L(V_R=16.8\text{ В}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{Z1}=5.0\text{ mA}) < 30\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•n.c•K
YA	RN2101	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_{\theta J/R_{\theta C}}=4.7\text{ К}/4.7\text{ К}/\text{К}$	SOT416,SC75A	B•E•C
YA	RN2101F	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_{\theta J/R_{\theta C}}=4.7\text{ К}/\text{К}/4.7\text{ К}/\text{К}$	SOT490,SC89	B•E•C
YA	RN2101FT	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_{\theta J/R_{\theta C}}=4.7\text{ К}/\text{К}/4.7\text{ К}/\text{К}$	TESM	B•E•C
YA	RN2301	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=200\text{ МГц}; R_{\theta J/R_{\theta C}}=4.7\text{ К}/\text{К}/4.7\text{ К}/\text{К}$	SOT323,SC70	B•E•C
YA	RN2401	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; f_T=200\text{ МГц}; R_{\theta J/R_{\theta C}}=4.7/4.7\text{ К}/\text{К}$	SOT346,SC59	B•E•C
YA-	2SC4784	REN	npn	$V_{CE0}=15\text{ В}; I_C=20\text{ mA}; P_D=100\text{ мВт}; h_{FE}=50\dots250; f_T > 7\text{ ГГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
YA-	2SC5049	REN	npn	$V_{CE0}=15\text{ В}; I_C=20\text{ mA}; P_D=150\text{ мВт}; h_{FE}=50\dots250; f_T > 7\text{ ГГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
YA-	2SC5543	REN	npn	$V_{CE0}=15\text{ В}; I_C=20\text{ mA}; P_D=80\text{ мВт}; h_{FE}=85\dots170; f_T > 5.5\text{ ГГц}$	SC81,MFPK	C•B•E
YB	RN2102	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_{\theta J/R_{\theta C}}=10/10/10\text{ К}/\text{К}$	SOT416,SC75A	B•E•C
YB	RN2102F	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_{\theta J/R_{\theta C}}=10/10/10\text{ К}/\text{К}$	SOT490,SC89	B•E•C
YB	RN2102FT	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_{\theta J/R_{\theta C}}=10/10/10\text{ К}/\text{К}$	TESM	B•E•C
YB	RN2302	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=200\text{ МГц}; R_{\theta J/R_{\theta C}}=10\text{ К}/\text{К}/10\text{ К}/\text{К}$	SOT323,SC70	B•E•C
YB	RN2402	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; f_T=200\text{ МГц}; R_{\theta J/R_{\theta C}}=10/10/10\text{ К}/\text{К}$	SOT346,SC59	B•E•C
YBs	BSS84	INF	pMOS	$V_{DS}=50\text{ В}; I_D=130\text{ mA}; P_D=360\text{ мВт}; g_m=50\text{ мСм}; R_{DS(on)} \leq 10\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	G•S•D
YC	RN2103	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=200\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_{\theta J/R_{\theta C}}=22/22\text{ К}/\text{К}$	SOT416,SC75A	B•E•C
YC	RN2103F	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_{\theta J/R_{\theta C}}=22/22\text{ К}/\text{К}$	SOT490,SC89	B•E•C
YC	RN2103FT	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_{\theta J/R_{\theta C}}=22/22\text{ К}/\text{К}$	TESM	B•E•C
YC	RN2303	TOSH	Dpnp	$V_{CE0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ mA}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=200\text{ МГц}; R_{\theta J/R_{\theta C}}=22\text{ К}/\text{К}/22\text{ К}/\text{К}$	SOT323,SC70	B•E•C

SOT490 TESH MFPK **TESM TSFP-3**

VMT3 VMD3  

SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3  

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
YC	RN2403	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 22/22 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
YD	RN2104	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 47/47 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
YD	RN2104F	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 47/47 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
YD	RN2104FT	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 47/47 кОм$	TESM	B-E-C
YD	RN2304	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 47 кОм/47 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
YD	RN2404	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 47/47 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
YE	RN2105	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 2.2/47 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
YE	RN2105F	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 2.2/47 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
YE	RN2105FT	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 2.2/47 кОм$	TESM	B-E-C
YE	RN2305	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 2.2 кОм/47 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
YE	RN2405	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 2.2/47 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
YF	RN2106	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 4.7/47 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
YF	RN2106F	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 4.7/47 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
YF	RN2106FT	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 4.7/47 кОм$	TESM	B-E-C
YF	RN2306	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 4.7 кОм/47 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
YF	RN2406	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 4.7/47 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
YH	RN2107	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 4.7/47 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
YH	RN2107F	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 10/47 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
YH	RN2107FT	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 10/47 кОм$	TESM	B-E-C
YH	RN2307	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 10 кОм/47 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
YH	RN2407	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 10/47 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
YI-	2SC4899	REN	npn	$V_{CE0} = 15 В; I_C = 20 мА; P_D = 100 мВт; h_{FE1} = 50 \dots 250; f_T > 6 ГГц$	SOT323, SC70	B-E-C
YI-	RN2108	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 22/47 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
YI	RN2108F	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 22/47 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
YI	RN2108FT	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 22/47 кОм$	TESM	B-E-C
YI	RN2308	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 22 кОм/47 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
YI	RN2408	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 22/47 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
YJ	RN2109	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 47/22 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
YJ	RN2109F	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 47/22 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
YJ	RN2109FT	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 47/22 кОм$	TESM	B-E-C
YJ	RN2309	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 47 кОм/22 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
YJ	RN2409	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 47/22 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
YK	RN2110	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 4.7 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
YK	RN2110F	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 4.7 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
YK	RN2110FT	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 4.7 кОм$	TESM	B-E-C
YK	RN2310	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 4.7 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
YK	RN2410	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 4.7 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
YK-	2SC4901	REN	npn	$V_{CE0} = 15 В; I_C = 50 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE1} = 50 \dots 250; f_T > 6 ГГц$	SOT323, SC70	B-E-C
YL-	2SC4902	REN	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE1} = 50 \dots 250; f_T > 4 ГГц$	SOT23, SOD23	B-E-C
YL-	2SC4903	REN	npn	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 30 мА; P_D = 150 мВт; h_{FE1} = 50 \dots 250; f_T > 4 ГГц$	SOT323, SC70	B-E-C
YM	RN2111	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 10 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
YM	RN2111F	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 10 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
YM	RN2111FT	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 10 кОм$	TESM	B-E-C
YM	RN2311	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 10 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
YM	RN2411	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 10 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
YN	RN2112	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 22 кОм$	SOT416, SC75A	B-E-C
YN	RN2112F	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 22 кОм$	SOT490, SC89	B-E-C
YN	RN2112FT	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 22 кОм$	TESM	B-E-C
YN	RN2312	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 22 кОм$	SOT323, SC70	B-E-C
YN	RN2412	TOSH	DnpP	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 200 МГц; R_{\theta J/R_1/R_2} = 22 кОм$	SOT346, SC59	B-E-C
YP	2SD1484KP	ROHM	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE1} = 82 \dots 180; f_T > 250 МГц$	SOT346, SC59	B-E-C
YP	2SD1949P	ROHM	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 500 мА; P_D = 200 мВт; h_{FE1} = 82 \dots 180; f_T > 250 МГц$	SOT323, SC70	B-E-C



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TSM VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3
YP	RN2113	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=250 МГц; R_T=47 кОм$	SOT416, SC75A	В•Е•С
YP	RN213F	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_T=47 кОм$	SOT490, SC89	В•Е•С
YP	RN213FT	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=250 МГц; R_T=47 кОм$	TESM	В•Е•С
YP	RN2313	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_T=47 кОм$	SOT323, SC70	В•Е•С
YP	RN2413	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_T=47 кОм$	SOT346, SC59	В•Е•С
YQ	2SD1484KQ	ROHM	npn	$V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{FE1}: 120...270; f_T > 250 МГц$	SOT346, SC59	В•Е•С
YQ	2SD1949Q	ROHM	npn	$V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{FE1}: 120...270; f_T > 250 МГц$	SOT323, SC70	В•Е•С
YQ	RN2114	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_T/R_2=1 кОм/10 кОм$	SOT416, SC75A	В•Е•С
YQ	RN2314	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_T/R_2=1 кОм/10 кОм$	SOT323, SC70	В•Е•С
YQ	RN2414	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_T/R_2=1/10 кОм$	SOT346, SC59	В•Е•С
YR	2SD1484KR	ROHM	npn	$V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{FE1}: 120...390; f_T > 250 МГц$	SOT346, SC59	В•Е•С
YR	2SD1949R	ROHM	npn	$V_{CBO}=50 В; I_C=500 мА; P_D=200 мВт; h_{FE1}: 180...390; f_T > 250 МГц$	SOT323, SC70	В•Е•С
YR	MSD601R	MOT	npn	$V_{CBO}=25 В$	SOT346, SC59	В•Е•С
YS	MSD601S	MOT	npn	$V_{CBO}=25 В$	SOT346, SC59	В•Е•С
YS	RN2115	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_T/R_2=2.2 кОм/10 кОм$	SOT416, SC75A	В•Е•С
YS	RN2315	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_T/R_2=2.2 кОм/10 кОм$	SOT323, SC70	В•Е•С
YS	RN2415	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_T/R_2=2.2/10 кОм$	SOT346, SC59	В•Е•С
YT	RN2116	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_T/R_2=4.7 кОм/10 кОм$	SOT416, SC75A	В•Е•С
YT	RN2316	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_T/R_2=4.7 кОм/10 кОм$	SOT323, SC70	В•Е•С
YT	RN2416	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_T/R_2=4.7/10 кОм$	SOT346, SC59	В•Е•С
YU	RN2117	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_T/R_2=10 кОм/4.7 кОм$	SOT416, SC75A	В•Е•С
YU	RN2317	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_T/R_2=10 кОм/4.7 кОм$	SOT323, SC70	В•Е•С
YU	RN2417	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_T/R_2=10/4.7 кОм$	SOT346, SC59	В•Е•С
YV-	2SC4964	REN	npn	$V_{CBO}=12 В; I_C=100 мА; P_D=150 мВт; h_{FE1}: 100...600$	SOT23, SOD23	В•Е•С
YV-	2SC4965	REN	npn	$V_{CBO}=12 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; h_{FE1}: 100...600$	SOT323, SC70	В•Е•С
YW	RN2118	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_T/R_2=47 кОм/10 кОм$	SOT416, SC75A	В•Е•С
YW	RN2318	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=100 мВт; f_T=200 МГц; R_T/R_2=47 кОм/10 кОм$	SOT323, SC70	В•Е•С
YW	RN2418	TOSH	Dpnp	$V_{CBO}=50 В; I_C=100 мА; P_D=200 мВт; f_T=200 МГц; R_T/R_2=47/10 кОм$	SOT346, SC59	В•Е•С
YY1	CMPZDA11V	CSI	dz-2	$V_{Z1}(I_Z=5 мА)=10.4...11.6 В; I_L(V_R=8.0 В) < 0.1 мкА; Z_{T1}(I_Z=5.0 мА) < 20 Ом; I_{ZM}=15 мА$	SOT23, SOD23	K2•K1•A2,A1
YY2	CMPZDA12V	CSI	dz-2	$V_{Z1}(I_Z=5 мА)=11.4...12.7 В; I_L(V_R=8.0 В) < 0.1 мкА; Z_{T1}(I_Z=5.0 мА) < 25 Ом; I_{ZM}=13 мА$	SOT23, SOD23	K2•K1•A2,A1
YY3	CMPZDA13V	CSI	dz-2	$V_{Z1}(I_Z=5 мА)=12.4...14.1 В; I_L(V_R=8.0 В) < 0.1 мкА; Z_{T1}(I_Z=5.0 мА) < 30 Ом; I_{ZM}=12 мА$	SOT23, SOD23	K2•K1•A2,A1
YY4	CMPZDA15V	CSI	dz-2	$V_{Z1}(I_Z=5 мА)=13.8...15.6 В; I_L(V_R=10.5 В) < 0.05 мкА; Z_{T1}(I_Z=5.0 мА) < 30 Ом; I_{ZM}=11 мА$	SOT23, SOD23	K2•K1•A2,A1
YY5	CMPZDA16V	CSI	dz-2	$V_{Z1}(I_Z=5 мА)=15.3...17.1 В; I_L(V_R=11.2 В) < 0.05 мкА; Z_{T1}(I_Z=5.0 мА) < 40 Ом; I_{ZM}=10 мА$	SOT23, SOD23	K2•K1•A2,A1
YY6	CMPZDA18V	CSI	dz-2	$V_{Z1}(I_Z=5 мА)=16.8...19.1 В; I_L(V_R=12.6 В) < 0.05 мкА; Z_{T1}(I_Z=5.0 мА) < 45 Ом; I_{ZM}=9.2 мА$	SOT23, SOD23	K2•K1•A2,A1
YY7	CMPZDA20V	CSI	dz-2	$V_{Z1}(I_Z=5 мА)=18.8...21.2 В; I_L(V_R=14.0 В) < 0.05 мкА; Z_{T1}(I_Z=5.0 мА) < 55 Ом; I_{ZM}=8.3 мА$	SOT23, SOD23	K2•K1•A2,A1
YY8	CMPZDA22V	CSI	dz-2	$V_{Z1}(I_Z=5 мА)=20.8...23.3 В; I_L(V_R=15.4 В) < 0.05 мкА; Z_{T1}(I_Z=5.0 мА) < 55 Ом; I_{ZM}=7.6 мА$	SOT23, SOD23	K2•K1•A2,A1
YY9	CMPZDA24V	CSI	dz-2	$V_{Z1}(I_Z=5 мА)=22.8...25.6 В; I_L(V_R=16.8 В) < 0.05 мкА; Z_{T1}(I_Z=5.0 мА) < 70 Ом; I_{ZM}=7.0 мА$	SOT23, SOD23	K2•K1•A2,A1
YZ-	2SC5050	REN	npn	$V_{CBO}=15 В; I_C=50 мА; P_D=150 мВт; h_{FE1}: 50...250; f_T > 8 ГГц$	SOT23, SOD23	В•Е•С
YZ-	2SC5051	REN	npn	$V_{CBO}=15 В; I_C=50 мА; P_D=100 мВт; h_{FE1}: 50...250; f_T > 8 ГГц$	SOT323, SC70	В•Е•С
YZ-	2SC5544	REN	npn	$V_{CBO}=15 В; I_C=50 мА; P_D=80 мВт; h_{FE1}: 85...170; f_T > 3 ГГц$	SC81, MFPK	С•В•Е
Z0	SS310	SIL	nFET	$V_{DS}=25 В; P_D=350 мВт; I_{DSS}=24...60 мА; g_{fs}=10 мСм$	SOT23, SOD23	D•S•G
Z1	BZX84C4V7	ALLEG	dz	$V_{Z1}(I_Z=5 мА)=4.4...5.0 В; I_L(V_R=2.0 В) < 3.0 мкА; Z_{T1}(I_Z=5 мА) < 80 Ом$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
Z1	BZX84C4V7	CSI	dz	$V_{Z1}(I_Z=5 мА)=4.4...5.0 В; I_L(V_R=2.0 В) < 3.0 мкА; Z_{T1}(I_Z=5 мА) < 80 Ом; I_{ZM}=53 мА$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K
Z1	BZX84C4V7	VISH	dz	$V_{Z1}(I_Z=5 мА)=4.4...5.0 В; Z_{T1}(I_Z=5 мА) < 80 Ом$	SOT23, SOD23	A•n.c.•K

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3 VMD3



SOT416 SOT523

SOT323 SOT346

SOT23-3 SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
Z1	BZX84C4V7LT1	MOT	dz	$V_{(I_{ZT}=5\text{ mA})}$: 4...5.0 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 80\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z1	RN2357	TOSH	Dnpnp	V_{CEB} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 100 мВт; f_T : 200 МГц; R_{11}/R_{12} : 10 кОм/47 кОм	SOT323, SC70	B•E•C
Z1	SSTJ211	SIL	nFET	V_{DS} : 25 В; P_D : 350 мВт; I_{DSS} : 7 мА; g_m : 7 мСм	SOT23, SOD23	D•S•G
Z11	BZX84C2V4	PHIL	dz	$V_{(I_{ZT}=5.0\text{ mA})}$: 2.2...2.6 В; $I_L(V_R=1.0\text{ B}) < 50\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 100\text{ Ом}$; I_{ZM} : 200 мА	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z11	BZX84C2V4LT1	MOT	dz	$V_{(I_{ZT}=5.0\text{ mA})}$: 2.2...2.6 В; $I_L(V_R=1.0\text{ B}) < 50\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 100\text{ Ом}$; I_{ZM} : 200 мА	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z12	BZX84C2V7	PHIL	dz	$V_{(I_{ZT}=5.0\text{ mA})}$: 2.5...2.9 В; $I_L(V_R=1.0\text{ B}) < 20\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 100\text{ Ом}$; I_{ZM} : 200 мА	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z12	BZX84C2V7	VISH	dz	$V_{(I_{ZT}=5\text{ mA})}$: 2.51...2.89 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 100\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z13	BZX84C3V0	PHIL	dz	$V_{(I_{ZT}=5.0\text{ mA})}$: 2.8...3.2 В; $I_L(V_R=1.0\text{ B}) < 10\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 95\text{ Ом}$; I_{ZM} : 200 мА	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z13	BZX84C3V0	VISH	dz	$V_{(I_{ZT}=5.0\text{ mA})}$: 2.8...3.2 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 100\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z13	BZX84-C3V0LT1	MOT	dz	$V_{(I_{ZT}=5.0\text{ mA})}$: 2.8...3.2 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 100\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z14	BZX84C3V3	PHIL	dz	$V_{(I_{ZT}=5.0\text{ mA})}$: 3.1...3.5 В; $I_L(V_R=1.0\text{ B}) < 5\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 95\text{ Ом}$; I_{ZM} : 200 мА	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z14	BZX84C3V3	VISH	dz	$V_{(I_{ZT}=5\text{ mA})}$: 3.1...3.5 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 95\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z15	BZX84C3V6	PHIL	dz	$V_{(I_{ZT}=5.0\text{ mA})}$: 3.4...3.8 В; $I_L(V_R=1.0\text{ B}) < 5\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 90\text{ Ом}$; I_{ZM} : 200 мА	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z15	BZX84C3V6	VISH	dz	$V_{(I_{ZT}=5\text{ mA})}$: 3.4...3.8 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 95\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z16	BZX84C3V9	PHIL	dz	$V_{(I_{ZT}=5.0\text{ mA})}$: 3.7...4.1 В; $I_L(V_R=1.0\text{ B}) < 3\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 90\text{ Ом}$; I_{ZM} : 200 мА	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z16	BZX84C3V9	VISH	dz	$V_{(I_{ZT}=5\text{ mA})}$: 3.7...4.1 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 90\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z17	BZX84C4V3	PHIL	dz	$V_{(I_{ZT}=5.0\text{ mA})}$: 4.0...4.6 В; $I_L(V_R=1.0\text{ B}) < 3\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 90\text{ Ом}$; I_{ZM} : 200 мА	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z17	BZX84C4V3	VISH	dz	$V_{(I_{ZT}=5\text{ mA})}$: 4.0...4.6 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 90\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z1A	BC846A	ZETEX	nnpn	V_{CEB} : 80 В; I_C : 100 мА; P_D : 330 мВт; h_{21} : 110...220; f_T : 300 МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
Z1E	BC847A	ZETEX	nnpn	V_{CEB} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 330 мВт; h_{21} : 110...220; f_T : 300 МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
Z1L	BC848C	ZETEX	nnpn	V_{CEB} : 30 В; I_C : 100 мА; P_D : 330 мВт; h_{21} : 420...800; f_T : 300 МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
Z1p	BZX84C4V7	PHIL	dz	$V_{(I_{ZT}=5.0\text{ mA})}$: 4.4...5.0 В; $I_L(V_R=2.0\text{ B}) < 3\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 80\text{ Ом}$; I_{ZM} : 200 мА	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z1t	BZX84C4V7	PHIL	dz	$V_{(I_{ZT}=5.0\text{ mA})}$: 4.4...5.0 В; $I_L(V_R=2.0\text{ B}) < 3\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 80\text{ Ом}$; I_{ZM} : 200 мА	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z2	BZX84C5V1	ALLEG	dz	$V_{(I_{ZT}=5\text{ mA})}$: 4.8...5.4 В; $I_L(V_R=2.0\text{ B}) < 2.0\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 60\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z2	BZX84C5V1	CSI	dz	$V_{(I_{ZT}=5\text{ mA})}$: 4.8...5.4 В; $I_L(V_R=2.0\text{ B}) < 2.0\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 60\text{ Ом}$; I_{ZM} : 49 мА	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z2	BZX84C5V1	VISH	dz	$V_{(I_{ZT}=5\text{ mA})}$: 4.8...5.4 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 60\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z2	SSTJ212	SIL	nFET	V_{DS} : 25 В; P_D : 350 мВт; I_{DSS} : 15 мА; g_m : 7 мСм	SOT23, SOD23	D•S•G
Z21	DT1C113ZE	ROHM	Dnpnp	V_{CEB} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 150 мВт; h_{21} : 233; f_T : 250 МГц; R_{11}/R_{12} : 1/10 кОм	SOT416, SC75A	B•E•C
Z21	DT1C113ZKA	ROHM	Dnpnp	V_{CEB} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 233; f_T : 250 МГц; R_{11}/R_{12} : 1/10 кОм	SOT346, SC59	B•E•C
Z21	DT1C113ZUA	ROHM	Dnpnp	V_{CEB} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 200 мВт; h_{21} : 233; f_T : 250 МГц; R_{11}/R_{12} : 1/10 кОм	SOT323, SC70	B•E•C
Z2G	BC850C	ZETEX	nnpn	V_{CEB} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 330 мВт; h_{21} : 420...800; f_T : 300 МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
Z2p	BZX84C5V1	PHIL	dz	$V_{(I_{ZT}=5.0\text{ mA})}$: 4.8...5.4 В; $I_L(V_R=2.0\text{ B}) < 2\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 60\text{ Ом}$; I_{ZM} : 200 мА	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z2t	BZX84C5V1	PHIL	dz	$V_{(I_{ZT}=5.0\text{ mA})}$: 4.8...5.4 В; $I_L(V_R=2.0\text{ B}) < 2\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 60\text{ Ом}$; I_{ZM} : 200 мА	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z2U	FMMTA63	ZETEX	pnp	V_{CEB} : 30 В; I_C : 500 мА; P_D : 330 мВт; h_{21} : 10000; f_T : 125 МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
Z2V	FMMTA64	ZETEX	pnp	V_{CEB} : 30 В; I_C : 500 мА; P_D : 330 мВт; h_{21} : 20000; f_T : 125 МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
Z3	BZX84C5V6	ALLEG	dz	$V_{(I_{ZT}=5\text{ mA})}$: 5.2...6.0 В; $I_L(V_R=2.0\text{ B}) < 1.0\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 40\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z3	BZX84C5V6	CSI	dz	$V_{(I_{ZT}=5\text{ mA})}$: 5.2...6.0 В; $I_L(V_R=2.0\text{ B}) < 1.0\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 40\text{ Ом}$; I_{ZM} : 45 мА	SOT23, SOD23	A•н.с.•К
Z3	BZX84C5V6	VISH	dz	$V_{(I_{ZT}=5\text{ mA})}$: 5.2...6.0 В; $Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 40\text{ Ом}$	SOT23, SOD23	A•н.с.~К
Z3B	BC856B	ZETEX	pnp	V_{CEB} : 80 В; I_C : 100 мА; P_D : 330 мВт; h_{21} : 220...475; f_T : 150 МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
Z3E	BC857A	ZETEX	pnp	V_{CEB} : 50 В; I_C : 100 мА; P_D : 330 мВт; h_{21} : 125...250; f_T : 150 МГц	SOT23, SOD23	B•E•C
Z3p	BZX84C5V6	PHIL	dz	$V_{(I_{ZT}=5.0\text{ mA})}$: 5.2...6.0 В; $I_L(V_R=2.0\text{ B}) < 1\text{ мкА}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 40\text{ Ом}$; I_{ZM} : 200 мА	SOT23, SOD23	A•н.с.~К



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490
MFPK

TESM
TSFP-3

VMT3
VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
Z3t	BZX84C5V6	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA})=5.2...6.0 \text{ B}; I_L(V_R=2.0 \text{ B}) < 1 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 40 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z4	BZX84C6V2	ALLEG	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=5.8...6.6 \text{ B}; I_L(V_R=4.0 \text{ B}) < 3.0 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA}) < 10 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z4	BZX84C6V2	CSI	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=5.8...6.6 \text{ B}; I_L(V_R=4.0 \text{ B}) < 3.0 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA}) < 10 \text{ Ом}; I_{ZM} < 40 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z4	BZX84C6V2	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=5.8...6.6 \text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA}) < 10 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z4A	BC859A	ZETEX	pnnp	$V_{CE0}=30 \text{ B}; I_C=100 \text{ mA}; P_D=330 \text{ мВт}; I_{B21}=125...250; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	В•Е•С
Z4C	BC859C	ZETEX	pnnp	$V_{CE0}=30 \text{ B}; I_C=100 \text{ mA}; P_D=330 \text{ мВт}; I_{B21}=420...800; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	В•Е•С
Z4E	BC860A	ZETEX	pnnp	$V_{CE0}=50 \text{ B}; I_C=100 \text{ mA}; P_D=330 \text{ мВт}; I_{B21}=125...250; f_T > 300 \text{ МГц}$	SOT23,SOD23	В•Е•С
Z4p	BZX84C6V2	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA})=5.8...6.6 \text{ B}; I_L(V_R=4.0 \text{ B}) < 3 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 10 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z4t	BZX84C6V2	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA})=5.8...6.6 \text{ B}; I_L(V_R=4.0 \text{ B}) < 3 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 10 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z5	BZX84C6V8	ALLEG	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=6.4...7.2 \text{ B}; I_L(V_R=4.0 \text{ B}) < 2.0 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z5	BZX84C6V8	CSI	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=6.4...7.2 \text{ B}; I_L(V_R=4.0 \text{ B}) < 2.0 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}; I_{ZM} < 37 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z5	BZX84C6V8	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=6.4...7.2 \text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z50	BZX84B2V4	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=2.4...2.5 \text{ B}; I_L(V_R=1.0 \text{ B}) < 50 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 100 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z51	BZX84B2V7	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=2.68...2.75 \text{ B}; I_L(V_R=1.0 \text{ B}) < 20 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 100 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z52	BZX84B3V0	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=2.94...3.06 \text{ B}; I_L(V_R=1.0 \text{ B}) < 10 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 95 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z53	BZX84B3V3	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=3.23...3.37 \text{ B}; I_L(V_R=1.0 \text{ B}) < 5 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 95 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z54	BZX84B3V6	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=3.53...3.67 \text{ B}; I_L(V_R=1.0 \text{ B}) < 5 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 90 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z55	BZX84B3V9	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=3.82...3.98 \text{ B}; I_L(V_R=1.0 \text{ B}) < 3 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 90 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z56	BZX84B4V3	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=4.21...4.39 \text{ B}; I_L(V_R=1.0 \text{ B}) < 3 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 90 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z57	BZX84B4V7	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=4.61...4.79 \text{ B}; I_L(V_R=2.0 \text{ B}) < 3 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 80 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z58	BZX84B5V1	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=5.00...5.20 \text{ B}; I_L(V_R=2.0 \text{ B}) < 2 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 60 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z59	BZX84B5V6	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=5.49...5.71 \text{ B}; I_L(V_R=2.0 \text{ B}) < 1 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 40 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z5p	BZX84C6V8	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=6.4...7.2 \text{ B}; I_L(V_R=4.0 \text{ B}) < 2 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z5t	BZX84C6V8	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=6.4...7.2 \text{ B}; I_L(V_R=4.0 \text{ B}) < 2 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z6	BZX84C7V5	ALLEG	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=7.0...7.9 \text{ B}; I_L(V_R=5.0 \text{ B}) < 1.0 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z6	BZX84C7V5	CSI	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=7.0...7.9 \text{ B}; I_L(V_R=5.0 \text{ B}) < 1.0 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}; I_{ZM} < 33 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z6	BZX84C7V5	VISH	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=7.0...7.9 \text{ B}; Z_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z60	BZX84B6V2	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=6.08...6.32 \text{ B}; I_L(V_R=4.0 \text{ B}) < 3 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 10 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z61	BZX84B6V8	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=6.66...6.94 \text{ B}; I_L(V_R=4.0 \text{ B}) < 2 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z62	BZX84B7V5	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=7.35...7.65 \text{ B}; I_L(V_R=5.0 \text{ B}) < 1 \text{ мкА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z63	BZX84B8V2	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=8.04...8.36 \text{ B}; I_L(V_R=5.0 \text{ B}) < 700 \text{ нА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z64	BZX84B9V1	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=8.92...9.28 \text{ B}; I_L(V_R=6.0 \text{ B}) < 500 \text{ нА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 15 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К
Z65	BZX84B10	PHIL	dz	$V_{21}(I_{ZT}=5 \text{ mA})=9.8...10.2; I_L(V_R=7.0 \text{ B}) < 200 \text{ нА}; Z_{21}(I_{ZT}=5.0 \text{ mA}) < 20 \text{ Ом}; I_{ZM}=200 \text{ mA}$	SOT23,SOD23	А•н.с•К

SOT490 TSM
MFFPAK TSFP-3

VMT3
VMD3



SOT416
SOT523

SOT323
SOT346

SOT23-3
SOD23-3



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
Z66	BZX84B11	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=10.8\dots 11.2\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=8.0\text{ B}) < 100\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=5.0\text{ mA}) < 20\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z67	BZX84B12	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=11.8\dots 12.2\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=8.0\text{ B}) < 100\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=5.0\text{ mA}) < 25\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z68	BZX84B13	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=12.7\dots 13.3\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=8.0\text{ B}) < 100\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=5.0\text{ mA}) < 30\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z69	BZX84B15	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=14.7\dots 15.3\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=10.5\text{ B}) < 0.05\text{ мкА};$ $Z_{T1}(I_{z1}=5.0\text{ mA}) < 30\text{ Ом}; I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z6p	BZX84C7V5	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=7.0\dots 7.9\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=5.0\text{ B}) < 1\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{z1}=5.0\text{ mA}) < 15\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z6i	BZX84C7V5	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=7.0\dots 7.9\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=5.0\text{ B}) < 1\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{z1}=5.0\text{ mA}) < 15\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z7	BZX84C8V2	ALLEG	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=7.7\dots 8.7\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=5.0\text{ B}) < 0.7\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{z1}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z7	BZX84C8V2	CSI	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=7.7\dots 8.9\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=5.0\text{ B}) < 0.7\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{z1}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом};$ $I_{z2M}=30\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z7	BZX84C8V2	VISH	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=7.7\dots 8.9\text{ B}; Z_{T1}(I_{z1}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z70	BZX84B16	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=15.7\dots 16.3\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=11.2\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=5.0\text{ mA}) < 40\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z71	BZX84B18	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=17.6\dots 18.4\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=12.6\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=5.0\text{ mA}) < 45\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z72	BZX84B20	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=19.6\dots 20.4\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=14.0\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=5.0\text{ mA}) < 55\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z73	BZX84B22	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=21.6\dots 22.4\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=15.4\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=5.0\text{ mA}) < 55\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z74	BZX84B24	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=23.5\dots 24.5\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=16.8\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=5.0\text{ mA}) < 30\text{ Ом};$ $I_{z2M}=250\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z75	BZX84B27	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=2\text{ mA})=26.5\dots 27.5\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=18.9\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=2.0\text{ mA}) < 80\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z76	BZX84B30	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=2\text{ mA})=29.4\dots 30.6\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=21.0\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=2.0\text{ mA}) < 80\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z77	BZX84B33	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=2\text{ mA})=32.3\dots 33.7\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=23.1\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=2.0\text{ mA}) < 80\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z78	BZX84B36	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=2\text{ mA})=35.3\dots 36.7\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=25.2\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=2.0\text{ mA}) < 90\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z79	BZX84B39	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=2\text{ mA})=38.2\dots 39.8\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=27.3\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=2.0\text{ mA}) < 75\text{ Ом};$ $I_{z2M}=250\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z7p	BZX84C8V2	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=7.7\dots 8.7\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=5.0\text{ B}) < 700\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=5.0\text{ mA}) < 15\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z7i	BZX84C8V2	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=7.7\dots 8.7\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=5.0\text{ B}) < 700\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=5.0\text{ mA}) < 15\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z8	BZX84C9V1	ALLEG	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=8.5\dots 9.6\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=6.0\text{ B}) < 0.5\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{z1}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z8	BZX84C9V1	CSI	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=8.5\dots 9.6\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=6.0\text{ B}) < 0.5\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{z1}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом};$ $I_{z2M}=27\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.•K
Z8	BZX84C9V1	VISH	dz	$V_{z1}(I_{z1}=5\text{ mA})=8.5\dots 9.6\text{ B}; Z_{T1}(I_{z1}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Z8	SST308	SIL	nFET	$V_{DS}=25\text{ B}; P_D=350\text{ мВт}; I_{DSS}=12\dots 60\text{ mA}; g_{fs}=8\text{ МСм}$	SOT23,SOD23	D•S•G
Z80	BZX84B43	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=2\text{ mA})=42.1\dots 43.9\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=30.1\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=2\text{ mA}) < 150\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Z81	BZX84B47	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=2\text{ mA})=46.1\dots 47.9\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=32.9\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=2\text{ mA}) < 170\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Z82	BZX84B51	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=2\text{ mA})=50.0\dots 52.0\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=35.7\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=2\text{ mA}) < 180\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Z83	BZX84B56	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=2\text{ mA})=54.9\dots 57.1\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=39.2\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=2\text{ mA}) < 200\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Z84	BZX84B62	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=2\text{ mA})=60.8\dots 63.2\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=43.4\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=2\text{ mA}) < 215\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Z85	BZX84B68	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=2\text{ mA})=66.6\dots 69.4\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=47.6\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=2\text{ mA}) < 240\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K
Z86	BZX84B75	PHIL	dz	$V_{z1}(I_{z1}=2\text{ mA})=73.5\dots 76.5\text{ B}; I_{z1}(V_{z1}=52.5\text{ B}) < 50\text{ нА}; Z_{T1}(I_{z1}=2\text{ mA}) < 255\text{ Ом};$ $I_{z2M}=200\text{ mA}$	SOT23,SOD23	A•н.с.~K



SOT23-3 SOT323 SOT416
SOD23-3 SOT346 SOT523



SOT490 TSM VMT3
MFPK TSFP-3 VMD3

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3
Z8p	BZX84C9V1	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5\text{ mA})=8.5...9.6\text{ B}; I_{I}(V_R=6.0\text{ B}) < 500\text{ нА}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом};$ $I_{ZM}=200\text{ мА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z8t	BZX84C9V1	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5\text{ mA})=8.5...9.6\text{ B}; I_{I}(V_R=6.0\text{ B}) < 500\text{ нА}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом};$ $I_{ZM}=200\text{ мА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z9	BZX84C10	ALLEG	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5\text{ mA})=9.4...10.6\text{ B}; I_{I}(V_R=7.0\text{ B}) < 0.2\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 20\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z9	BZX84C10	VISH	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5\text{ mA})=9.4...10.6\text{ B}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 20\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z9	SST309	SIL	nFET	$V_{DS}=25\text{ B}; P_D=350\text{ мВт}; I_{OSS}=12...30\text{ мА}; g_m=10\text{ мСм}$	SOT23,SOD23	D•S•G
Z9p	BZX84C10	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5\text{ mA})=9.4...10.6\text{ B}; I_{I}(V_R=7.0\text{ B}) < 200\text{ нА}; Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 20\text{ Ом};$ $I_{ZM}=200\text{ мА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
Z9t	BZX84C10	PHIL	dz	$V_{ZT}(I_{ZT}=5\text{ mA})=9.4...10.6\text{ B}; I_{I}(V_R=7.0\text{ B}) < 200\text{ нА}; Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 20\text{ Ом};$ $I_{ZM}=200\text{ мА}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
ZA6	FMMD2838	ZETEX	fid-2	$V_R=75\text{ B}; I_C < 100\text{ мА}; V_{CE}(I_C=50\text{ mA}) < 1.0\text{ B}; I_B < 0.1\text{ мкА}; C_D < 4.0\text{ нФ}; I_{RR} < 6\text{ Hc}$	SOT23,SOD23	A1•A2•K1,K2
ZB	FMMT4123	ZETEX	npn	$V_{CE0}=40\text{ B}; I_C=200\text{ мА}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21}=50...150; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
ZC	FMMT4124	ZETEX	npn	$V_{CE0}=30\text{ B}; I_C=200\text{ мА}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21}=120...360; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
ZC	KST4124	SAMS	npn	$V_{CE0}=30\text{ B}; I_C=200\text{ мА}; P_D=350\text{ мВт}; h_{21}=120...360; f_T > 300\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
ZCA	KN3904S	KEC	npn	$V_{CE0}=60\text{ B}; I_C=200\text{ мА}; P_D=350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	B•E•C
ZD	FMMT4125	ZETEX	pnip	$V_{CE0}=30\text{ B}; I_C=200\text{ мА}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21}=50...150; f_T > 200\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
ZD	KST4125	SAMS	pnip	$V_{CE0}=30\text{ B}; I_C=200\text{ мА}; P_D=350\text{ мВт}; h_{21}=50...150; f_T > 200\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
ZE	FMMT4126	ZETEX	pnip	$V_{CE0}=25\text{ B}; I_C=200\text{ мА}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21} > 60; f_T > 250\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
ZFD	BCV26	ZETEX	dpnp	$V_{CE0}=40\text{ B}; I_C=500\text{ мА}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21} > 100; f_T > 200\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
ZFE	BCV46	ZETEX	dpnp	$V_{CE0}=80\text{ B}; I_C=500\text{ мА}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21} > 400; f_T > 200\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
ZFF	BCV27	ZETEX	dpnp	$V_{CE0}=40\text{ B}; I_C=500\text{ мА}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21} > 100; f_T > 170\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
ZFG	BCV47	ZETEX	dpnp	$V_{CE0}=80\text{ B}; I_C=500\text{ мА}; P_D=330\text{ мВт}; h_{21} > 400; f_T > 170\text{ МГц}$	SOT23,SOD23	B•E•C
ZK-	2S451	REN	pMOS	$V_{DS}=20\text{ B}; I_D=200\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; R_{DS(on)}=9\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	G•S•D
ZM-	2S452	REN	pMOS	$V_{DS}=50\text{ B}; I_D=200\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; R_{DS(on)}=12\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	G•S•D
ZQ	2PC4041R	PHIL	npn	$V_{CE0}=50\text{ B}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=120...270; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
ZR	2PC4081R	PHIL	npn	$V_{CE0}=50\text{ B}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=180...390; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
ZR	MSD1819ART1	MOT	npn	$V_{CE0}=60\text{ B}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}=210...340$	SOT323,SC70	B•E•C
ZRA	KN3903S	KEC	npn	$V_{CE0}=60\text{ B}; I_C=200\text{ мА}; P_D=350\text{ мВт}$	SOT23,SOD23	B•E•C
ZS	2PC4081S	PHIL	npn	$V_{CE0}=50\text{ B}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}=270...560; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT323,SC70	B•E•C
ZS-	2SC5702	REN	npn	$V_{CE0}=15\text{ B}; I_C=50\text{ мА}; P_D=80\text{ мВт}; h_{21}=80...160; f_T > 6.5\text{ ГГц}$	SC81,MFPK	B•E•C
ZS1	ZHCS1000	ZETEX	shd	$V_R < 40\text{ B}; I_C=1\text{ A}; V_{FI}(I_C=1\text{ A}) < 0.425\text{ B}; I_B < 100\text{ мкА}; C_D < 25\text{ нФ}; I_{RR} < 12\text{ Hc}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
ZS5	ZHCS500	ZETEX	shd	$V_R < 40\text{ B}; I_C < 0.5\text{ A}; V_{FI}(I_C=0.5\text{ A}) < 0.55\text{ B}; I_B < 40\text{ мкА}; C_D < 20\text{ нФ}; I_{RR} < 10\text{ Hc}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
ZS7	ZHCS750	ZETEX	shd	$V_R < 40\text{ B}; I_C < 0.75\text{ A}; V_{FI}(I_C=0.75\text{ A}) < 0.49\text{ B}; I_B < 0.1\text{ мкА}; C_D < 25\text{ нФ};$ $I_{RR} < 12\text{ Hc}$	SOT23,SOD23	A•n.c.•K
ZU-	2S486	REN	pMOS	$V_{DS}=30\text{ B}; I_D=300\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; R_{DS(on)} < 1.2\text{ Ом}$	SOT23,SOD23	G•S•D
ZZ1	CMPZDA4V7	CSI	dz-2	$V_{ZT}(I_{ZT}=5\text{ mA})=4.4...5.0\text{ B}; I_{I}(V_R=2.0\text{ B}) < 3.0\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 80\text{ Ом};$ $I_{ZM}=38\text{ мА}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ2	CMPZDA5V1	CSI	dz-2	$V_{ZT}(I_{ZT}=5\text{ mA})=4.8...5.4\text{ B}; I_{I}(V_R=2.0\text{ B}) < 2.0\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 60\text{ Ом};$ $I_{ZM}=35\text{ мА}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ3	CMPZDA5V6	CSI	dz-2	$V_{ZT}(I_{ZT}=5\text{ mA})=5.2...6.0\text{ B}; I_{I}(V_R=2.0\text{ B}) < 1.0\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 40\text{ Ом};$ $I_{ZM}=32\text{ мА}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ4	CMPZDA6V2	CSI	dz-2	$V_{ZT}(I_{ZT}=5\text{ mA})=5.8...6.6\text{ B}; I_{I}(V_R=4.0\text{ B}) < 3.0\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 10\text{ Ом};$ $I_{ZM}=28\text{ мА}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ5	CMPZDA6V8	CSI	dz-2	$V_{ZT}(I_{ZT}=5\text{ mA})=6.4...7.2\text{ B}; I_{I}(V_R=4.0\text{ B}) < 2.0\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом};$ $I_{ZM}=25\text{ мА}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ6	CMPZDA7V5	CSI	dz-2	$V_{ZT}(I_{ZT}=5\text{ mA})=7.0...7.9\text{ B}; I_{I}(V_R=5.0\text{ B}) < 1.0\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом};$ $I_{ZM}=23\text{ мА}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ7	CMPZDA8V2	CSI	dz-2	$V_{ZT}(I_{ZT}=5\text{ mA})=7.7...8.7\text{ B}; I_{I}(V_R=5.0\text{ B}) < 0.7\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом};$ $I_{ZM}=21\text{ мА}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ8	CMPZDA9V1	CSI	dz-2	$V_{ZT}(I_{ZT}=5\text{ mA})=8.5...9.6\text{ B}; I_{I}(V_R=6.0\text{ B}) < 0.5\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 15\text{ Ом};$ $I_{ZM}=18\text{ мА}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
ZZ9	CMPZDA10V	CSI	dz-2	$V_{ZT}(I_{ZT}=5\text{ mA})=9.4...10.6\text{ B}; I_{I}(V_R=7.0\text{ B}) < 0.2\text{ мкА}; Z_{T1}(I_{ZT}=5\text{ mA}) < 20\text{ Ом};$ $I_{ZM}=16\text{ мА}$	SOT23,SOD23	K2•K1•A2,A1
	2SA1666	REN	pnip	$V_{CE0}=15\text{ B}; I_C=200\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}=20...200; f_T=100\text{ МГц}$	SOT346,SC59	B•E•C

TO263
D2PAKTO252
DPAKSOT223
TO261ASOT89
SC62

SOT89/223, TO252/263...

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
21	Gali-21	MC	amp	InGaP; $f_{\text{ЭБ}} = 0...8$ ГГц; GAIN = 14 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
33	Gali-33	MC	amp	InGaP; $f_{\text{ЭБ}} = 0...4$ ГГц; GAIN = 19 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
51	Gali-51	MC	amp	InGaP; $f_{\text{ЭБ}} = 0...4$ ГГц; GAIN = 18 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
52	Gali-52	MC	amp	InGaP; $f_{\text{ЭБ}} = 0...2$ ГГц; GAIN = 23 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
55	Gali-55	MC	amp	InGaP; $f_{\text{ЭБ}} = 0...4$ ГГц; GAIN = 21 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
651	PZT651	ON	npn	$V_{\text{CB0}} = 80$ В; $I_C = 2$ А; $P_D = 0.8$ Вт; $h_{21} > 40$; $f_T > 75$ МГц	SOT-223, TO-261AA	B • C • E • C
720	BF720	STM	npn	$V_{\text{CB0}} = 300$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 1.5$ Вт; $h_{21} > 50$; $f_T = 60$ МГц	SOT-223, TO-261AA	B • C • E • C
721	BF721	STM	pnnp	$V_{\text{CB0}} = 300$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 1.5$ Вт; $h_{21} > 50$; $f_T = 60$ МГц	SOT-223, TO-261AA	B • C • E • C
—	BCX68	SIEM	npn	$V_{\text{CB0}} = 20$ В; $I_C = 1$ А; $P_D = 1$ Вт; $h_{21} = 85...375$; $f_T > 100$ МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
—	BCX69	SIEM	pnnp	$V_{\text{CB0}} = 20$ В; $I_C = 1$ А; $P_D = 1$ Вт; $h_{21} = 85...375$; $f_T > 100$ МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
01	Gali-1	MC	amp	InGaP; $f_{\text{ЭБ}} = 0...8$ ГГц; GAIN = 12 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
02	Gali-2	MC	amp	InGaP; $f_{\text{ЭБ}} = 0...8$ ГГц; GAIN = 16 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
03	Gali-3	MC	amp	InGaP; $f_{\text{ЭБ}} = 0...3$ ГГц; GAIN = 22 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
04	Gali-4	MC	amp	InGaP; $f_{\text{ЭБ}} = 0...4$ ГГц; GAIN = 17.5 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
05	Gali-4	MC	amp	InGaP; $f_{\text{ЭБ}} = 0...4$ ГГц; GAIN = 18 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
06	Gali-6	MC	amp	InGaP; $f_{\text{ЭБ}} = 0...4$ ГГц; GAIN = 11 дБ	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
0C	MC78LC30HT1	ON	reg	LDO; $V_N = 2.5...12$ В; $V_{\text{OUT}} = 3.0$ В; $I_{\text{OUT}} = 50$ мА	SOT-89, SC-62	GND • VIN • VOUT • VIN
0D	MC78LC40HT1	ON	reg	LDO; $V_N = 2.5...12$ В; $V_{\text{OUT}} = 4.0$ В; $I_{\text{OUT}} = 50$ мА	SOT-89, SC-62	GND • VIN • VOUT • VIN
0E	MC78LC50HT1	ON	reg	LDO; $V_N = 2.5...12$ В; $V_{\text{OUT}} = 5.0$ В; $I_{\text{OUT}} = 50$ мА	SOT-89, SC-62	GND • VIN • VOUT • VIN
10Y	BZV49C10	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5.0 \text{ мА}) = 9.4...10.6$ В; $Z_{\text{TT}} (I_{ZT} = 5.0 \text{ мА}) < 200 \text{ м}$; $I_{ZM} = 250 \text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
1117	LT1117CST	LT	reg	LDO; $V_N < 15$ В; $V_{\text{REF}} = 1.25$ В; $I_{\text{OUT}} = 800$ мА	SOT-223, TO-261AA	ADJ/GND • OUT • IN • OUT
11172	LT1117CST-2.85	LT	reg	LDO; $V_N < 15$ В; $V_{\text{OUT}} = 2.85$ В; $I_{\text{OUT}} = 800$ мА	SOT-223, TO-261AA	ADJ/GND • OUT • IN • OUT
11173	LT1117CST-3.3	LT	reg	LDO; $V_N < 15$ В; $V_{\text{OUT}} = 3.3$ В; $I_{\text{OUT}} = 800$ мА	SOT-223, TO-261AA	ADJ/GND • OUT • IN • OUT

**SOT89
SC62****SOT223
TO261A****TO252
DPAK****TO263
D2PAK**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4
11175	LT1117CST-5	LT	reg	LDO; $V_{IN} < 15\text{ В}$; $V_{OUT} = 5\text{ В}$; $I_{OUT} = 800\text{ мА}$	SOT-223, TO-261AA	ADJ/GND • OUT • IN • OUT
111825	LT1118CST-2.5	LT	reg	LDO; $V_{IN} < 15\text{ В}$; $V_{OUT} = 2.5\text{ В}$; $I_{OUT} = 800\text{ мА}$	SOT-223, TO-261AA	OUT • GND • IN • GND
111828	LT1118CST-2.85	LT	reg	LDO; $V_{IN} < 15\text{ В}$; $V_{OUT} = 2.85\text{ В}$; $I_{OUT} = 800\text{ мА}$	SOT-223, TO-261AA	OUT • GND • IN • GND
11185	LT1118CST-5	LT	reg	LDO; $V_{IN} < 15\text{ В}$; $V_{OUT} = 5\text{ В}$; $I_{OUT} = 800\text{ мА}$	SOT-223, TO-261AA	OUT • GND • IN • GND
11Y	BZV49C11	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) = 10.4...11.6\text{ В}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) < 20\text{ Ом}$; $I_{ZM} = 250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
12Y	BZV49C12	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) = 11.4...12.7\text{ В}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) < 25\text{ Ом}$; $I_{ZM} = 250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
13Y	BZV49C13	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) = 12.4...14.1\text{ В}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) < 30\text{ Ом}$; $I_{ZM} = 250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
15Y	BZV49C15	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) = 13.8...15.6\text{ В}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) < 30\text{ Ом}$; $I_{ZM} = 250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
16Y	BZV49C16	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) = 15.3...17.1\text{ В}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) < 40\text{ Ом}$; $I_{ZM} = 250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
18Y	BZV49C18	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) = 16.8...19.1\text{ В}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) < 45\text{ Ом}$; $I_{ZM} = 250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
1A	SXT3904	SIEM	npn	$V_{CBO} = 40\text{ В}$; $I_C = 200\text{ мА}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 100...300$; $f_T > 300\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1D	SXT4A2	SIEM	npn	$V_{CBO} = 300\text{ В}$; $I_C = 500\text{ мА}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} > 40$; $f_T > 50\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1E	SXTA43	SIEM	npn	$V_{CBO} = 200\text{ В}$; $I_C = 500\text{ мА}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} > 40$; $f_T > 50\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1XP	2SB1599P	PAN	pnip	$V_{CBO} = 50\text{ В}$; $I_C = 3\text{ А}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 50...100$; $f_T = 150\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1XQ	2SB1599Q	PAN	pnip	$V_{CBO} = 50\text{ В}$; $I_C = 3\text{ А}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 80...160$; $f_T = 150\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1XR	2SB1599R	PAN	pnip	$V_{CBO} = 50\text{ В}$; $I_C = 3\text{ А}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 100...220$; $f_T = 150\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1YQ	2SD2457Q	PAN	npn	$V_{CBO} = 50\text{ В}$; $I_C = 1.5\text{ А}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 80...160$; $f_T = 150\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1YR	2SD2457R	PAN	npn	$V_{CBO} = 50\text{ В}$; $I_C = 1.5\text{ А}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 120...220$; $f_T = 150\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1ZQ	2SA1890Q	PAN	pnip	$V_{CBO} = 80\text{ В}$; $I_C = 1\text{ А}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 120...240$; $f_T = 120\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
1ZR	2SA1890R	PAN	pnip	$V_{CBO} = 80\text{ В}$; $I_C = 1\text{ А}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 170...340$; $f_T = 120\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
20Y	BZV49C20	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) = 18.8...21.2\text{ В}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) < 55\text{ Ом}$; $I_{ZM} = 250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
22Y	BZV49C22	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) = 20.8...23.3\text{ В}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) < 55\text{ Ом}$; $I_{ZM} = 250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
24Y	BZV49C24	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) = 22.8...25.6\text{ В}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) < 70\text{ Ом}$; $I_{ZM} = 250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
27Y	BZV49C27	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT} = 2.0\text{ мА}) = 25.1...28.9\text{ В}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 2.0\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$; $I_{ZM} = 250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
2A	SXT3906	SIEM	pnip	$V_{CBO} = 40\text{ В}$; $I_C = 200\text{ мА}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 100...300$; $f_T > 250\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2AR	2SC5026R	PAN	npn	$V_{CBO} = 80\text{ В}$; $I_C = 1\text{ А}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 120...240$; $f_T = 120\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2AS	2SC5026S	PAN	npn	$V_{CBO} = 80\text{ В}$; $I_C = 1\text{ А}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 170...340$; $f_T = 120\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2AD	SXTA92	SIEM	pnip	$V_{CBO} = 300\text{ В}$; $I_C = 500\text{ мА}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} > 25$; $f_T > 50\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2E	SXTA93	SIEM	pnip	$V_{CBO} = 200\text{ В}$; $I_C = 500\text{ мА}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} > 25$; $f_T > 50\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2ER	2SD2459R	PAN	npn	$V_{CBO} = 150\text{ В}$; $I_C = 1\text{ А}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 120...240$; $f_T = 90\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2ES	2SD2459S	PAN	npn	$V_{CBO} = 150\text{ В}$; $I_C = 1\text{ А}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 170...340$; $f_T = 90\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2F	2SB1612	PAN	pnip	$V_{CBO} = 10\text{ В}$; $I_C = 2\text{ А}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 200...800$; $f_T = 60\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2F	SXT2907A	SIEM	pnip	$V_{CBO} = 60\text{ В}$; $I_C = 600\text{ мА}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 100...300$; $f_T > 200\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2I	2SD2474	PAN	npn	$V_{CBO} = 10\text{ В}$; $I_C = 2\text{ А}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 200...800$; $f_T = 180\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2P	SXT2222A	SIEM	npn	$V_{CBO} = 75\text{ В}$; $I_C = 600\text{ мА}$; $P_D = 1\text{ Вт}$; $h_{21} = 100...300$; $f_T > 300\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
2Y4	BZV49C2V4	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) = 2.2...2.6\text{ В}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$; $I_{ZM} = 250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
2Y7	BZV49C2V7	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) = 2.5...2.9\text{ В}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 5.0\text{ мА}) < 100\text{ Ом}$; $I_{ZM} = 250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
30Y	BZV49C30	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT} = 2.0\text{ мА}) = 28.0...32.0\text{ В}$; $Z_{T1} (I_{ZT} = 2.0\text{ мА}) < 80\text{ Ом}$; $I_{ZM} = 250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K

**TO263
D2PAK**



**TO252
DPAK**



**SOT223
TO261A**



**SOT89
SC62**



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4
33Y	BZV49C33	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.0\text{ mA})=31.0...35.0\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=2.0\text{ mA}) < 80\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
36Y	BZV49C36	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.0\text{ mA})=34.0...38.0\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=2.0\text{ mA}) < 90\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
37518	MC33375ST-1.8	ON	reg	LDO; $V_N=2.5...2.5...13\text{ B}$; $V_{OUT}=1.8\text{ B}$; $I_{OUT}=300\text{ mA}$	SOT-223, TO-261AA	IN• ON/OFF• OUT•GND
37525	MC33375ST-2.5	ON	reg	LDO; $V_N=2.5...13\text{ B}$; $V_{OUT}=2.5\text{ B}$; $I_{OUT}=300\text{ mA}$	SOT-223, TO-261AA	IN• ON/OFF• OUT•GND
37530	MC33375ST-3.0	ON	reg	LDO; $V_N=2.5...13\text{ B}$; $V_{OUT}=3.0\text{ B}$; $I_{OUT}=300\text{ mA}$	SOT-223, TO-261AA	IN• ON/OFF• OUT•GND
37533	MC33375ST-3.3	ON	reg	LDO; $V_N=2.5...13\text{ B}$; $V_{OUT}=3.3\text{ B}$; $I_{OUT}=300\text{ mA}$	SOT-223, TO-261AA	IN• ON/OFF• OUT•GND
37550	MC33375ST-5.0	ON	reg	LDO; $V_N=2.5...13\text{ B}$; $V_{OUT}=5.0\text{ B}$; $I_{OUT}=300\text{ mA}$	SOT-223, TO-261AA	IN• ON/OFF• OUT•GND
39Y	BZV49C39	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.0\text{ mA})=37.0...41.0\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=2.0\text{ mA}) < 130\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
3C	MC78LC33HT1	ON	reg	LDO; $V_N=2.5...12\text{ B}$; $V_{OUT}=3.3\text{ B}$; $I_{OUT}=50\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	GND•VIN• VOUT•VIN
3Y0	BZV49C3V0	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA})=2.8...3.2\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 95\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
3Y3	BZV49C3V3	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA})=3.1...3.5\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 95\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
3Y6	BZV49C3V6	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA})=3.4...3.8\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 90\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
3Y9	BZV49C3V9	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA})=3.7...4.1\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 90\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
43Y	BZV49C43	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.0\text{ mA})=40.0...46.0\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=2.0\text{ mA}) < 150\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
47Y	BZV49C47	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.0\text{ mA})=44.0...50.0\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=2.0\text{ mA}) < 170\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
4F	Gall-4F	MC	amp	InGaP; $f_{BD}=0...4\text{ ГГц}$; GAIN=15 дБ	SOT-89, SC-62	IN•GND• OUT, VD• GND
4Y3	BZV49C4V3	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA})=4.0...4.6\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 90\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
4Y7	BZV49C4V7	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA})=4.4...5.0\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 80\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
51Y	BZV49C51	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.0\text{ mA})=48.0...54.0\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=2.0\text{ mA}) < 180\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
56Y	BZV49C56	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.0\text{ mA})=52.0...60.0\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=2.0\text{ mA}) < 200\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
5F	Gall-5F	MC	amp	InGaP; $f_{BD}=0...4\text{ ГГц}$; GAIN=20 дБ	SOT-89, SC-62	IN•GND• OUT, VD• GND
5Y1	BZV49C5V1	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA})=4.8...5.4\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 60\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
5Y6	BZV49C5V6	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA})=5.2...6.0\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 40\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
62Y	BZV49C62	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.0\text{ mA})=58.0...66.0\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=2.0\text{ mA}) < 215\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
68Y	BZV49C68	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.0\text{ mA})=64.0...72.0\text{ B}$; $Z_{TZ}(I_{ZT}=2.0\text{ mA}) < 240\text{ Ом}$; $I_{ZM}=250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
6A	KIA7019AF	KEC	vd	$V_{REG}=1.9\text{ B}$; VCC(max)=15 B; $P_D=500\text{ мВт}$	SOT-89, SC-62	VCC•GND• OUT•GND
6B	KIA7021AF	KEC	vd	$V_{REG}=2.1\text{ B}$; VCC(max)=15 B; $P_D=500\text{ мВт}$	SOT-89, SC-62	VCC•GND• OUT•GND

**SOT89
SC62****SOT223
TO261A****TO52
DPAK****TO263
D2PAK**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4
6C	KIA7023AF	KEC	vd	$V_{RG}=2.3\text{ В}; V_{CC}(\text{max})=15\text{ В}; P_D=500\text{ мВт}$	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6D	KIA7025AF	KEC	vd	$V_{RG}=2.5\text{ В}; V_{CC}(\text{max})=15\text{ В}; P_D=500\text{ мВт}$	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6E	KIA7027AF	KEC	vd	$V_{RG}=2.7\text{ В}; V_{CC}(\text{max})=15\text{ В}; P_D=500\text{ мВт}$	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6F	Gali-6F	MC	amp	InGaP; $f_{BD}=0...4\text{ ГГц}; \text{GAIN}=12\text{ дБ}$	SOT-89, SC-62	IN • GND • OUT, VD • GND
6F	KIA7029AF	KEC	vd	$V_{RG}=2.9\text{ В}; V_{CC}(\text{max})=15\text{ В}; P_D=500\text{ мВт}$	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6G	KIA7031AF	KEC	vd	$V_{RG}=3.1\text{ В}; V_{CC}(\text{max})=15\text{ В}; P_D=500\text{ мВт}$	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6H	KIA7032AF	KEC	vd	$V_{RG}=3.2\text{ В}; V_{CC}(\text{max})=15\text{ В}; P_D=500\text{ мВт}$	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6J	KIA7033AF	KEC	vd	$V_{RG}=3.3\text{ В}; V_{CC}(\text{max})=15\text{ В}; P_D=500\text{ мВт}$	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6K	KIA7034AF	KEC	vd	$V_{RG}=3.4\text{ В}; V_{CC}(\text{max})=15\text{ В}; P_D=500\text{ мВт}$	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6L	KIA7035AF	KEC	vd	$V_{RG}=3.5\text{ В}; V_{CC}(\text{max})=15\text{ В}; P_D=500\text{ мВт}$	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6M	KIA7036AF	KEC	vd	$V_{RG}=3.6\text{ В}; V_{CC}(\text{max})=15\text{ В}; P_D=500\text{ мВт}$	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6N	KIA7039AF	KEC	vd	$V_{RG}=3.9\text{ В}; V_{CC}(\text{max})=15\text{ В}; P_D=500\text{ мВт}$	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6P	KIA7042AF	KEC	vd	$V_{RG}=4.2\text{ В}; V_{CC}(\text{max})=15\text{ В}; P_D=500\text{ мВт}$	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6R	KIA7045AF	KEC	vd	$V_{RG}=4.5\text{ В}; V_{CC}(\text{max})=15\text{ В}; P_D=500\text{ мВт}$	SOT-89, SC-62	VCC • GND • OUT • GND
6Y2	BZV49C6V2	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ мА})=5.8...6.6\text{ В}; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0\text{ мА}) < 10\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
6Y8	BZV49C6V8	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ мА})=6.4...7.2\text{ В}; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0\text{ мА}) < 15\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
75Y	BZV49C75	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=2.0\text{ мА})=70.0...79.0\text{ В}; Z_{ZT}(I_{ZT}=2.0\text{ мА}) < 255\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
7Y5	BZV49C7V5	PHIL	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ мА})=7.0...7.9\text{ В}; Z_{ZT}(I_{ZT}=5.0\text{ мА}) < 15\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
8A	NJM78L02A	NJR	reg	$V_{IN}=2.5...30\text{ В}; V_{OUT}=2.6\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8B	NJM78L03A	NJR	reg	$V_{IN}=2.5...30\text{ В}; V_{OUT}=3.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8C	NJM78L05A	NJR	reg	$V_{IN}=2.5...30\text{ В}; V_{OUT}=5.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8E	NJM78L06A	NJR	reg	$V_{IN}=2.5...30\text{ В}; V_{OUT}=6.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8F	NJM78L07A	NJR	reg	$V_{IN}=2.5...30\text{ В}; V_{OUT}=7.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8G	NJM78L08A	NJR	reg	$V_{IN}=2.5...30\text{ В}; V_{OUT}=8.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8H	NJM78L09A	NJR	reg	$V_{IN}=2.5...30\text{ В}; V_{OUT}=9.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8J	NJM78L10A	NJR	reg	$V_{IN}=2.5...35\text{ В}; V_{OUT}=10.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8K	NJM78L12A	NJR	reg	$V_{IN}=2.5...35\text{ В}; V_{OUT}=12.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8L	NJM78L15A	NJR	reg	$V_{IN}=2.5...35\text{ В}; V_{OUT}=15.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8M	NJM78L18A	NJR	reg	$V_{IN}=2.5...40\text{ В}; V_{OUT}=18.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND

**TO263
D2PAK**



**TO252
DPAK**



**SOT223
TO261A**



**SOT89
SC62**



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4
8N	NJM78L20A	NJR	reg	$V_{IN}=2.5...40\text{ В}; V_{OUT}=20.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8P	NJM78L24A	NJR	reg	$V_{IN}=2.5...40\text{ В}; V_{OUT}=24.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
8Y2	BZV49C8V2	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5.0\text{ мА})=7.7...8.7\text{ В}; Z_{ZT} (I_{ZT}=5.0\text{ мА}) < 15\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
8Z	NJM78L62A	NJR	reg	$V_{IN}=2.5...30\text{ В}; V_{OUT}=6.2\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	OUT • GND • IN • GND
9B	NJM79L03UA	NJR	reg	$V_{IN}=-2.5...-30\text{ В}; V_{OUT}=-3.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	GND • IN • OUT • IN
9C	NJM79L05UA	NJR	reg	$V_{IN}=-2.5...-30\text{ В}; V_{OUT}=-5.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	GND • IN • OUT • IN
9E	NJM79L06UA	NJR	reg	$V_{IN}=-2.5...-30\text{ В}; V_{OUT}=-5.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	GND • IN • OUT • IN
9G	NJM79L08UA	NJR	reg	$V_{IN}=-2.5...-30\text{ В}; V_{OUT}=-8.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	GND • IN • OUT • IN
9H	NJM79L09UA	NJR	reg	$V_{IN}=-2.5...-30\text{ В}; V_{OUT}=-8.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	GND • IN • OUT • IN
9K	NJM79L12UA	NJR	reg	$V_{IN}=-2.5...-35\text{ В}; V_{OUT}=-12.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	GND • IN • OUT • IN
9L	NJM79L15UA	NJR	reg	$V_{IN}=-2.5...-35\text{ В}; V_{OUT}=-15.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	GND • IN • OUT • IN
9M	NJM79L18UA	NJR	reg	$V_{IN}=-2.5...-40\text{ В}; V_{OUT}=-18.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	GND • IN • OUT • IN
9P	NJM79L24UA	NJR	reg	$V_{IN}=-2.5...-40\text{ В}; V_{OUT}=-24.0\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	GND • IN • OUT • IN
9Y1	BZV49C9V1	PHIL	dz	$V_Z (I_{ZT}=5.0\text{ мА})=8.5...9.6\text{ В}; Z_{ZT} (I_{ZT}=5.0\text{ мА}) < 15\text{ Ом}; I_{ZM}=250\text{ мА}$	SOT-89, SC-62	A • K • A • K
A27	PXTA27	PHIL	nprn	$V_{CB0}=60\text{ В}; I_C=500\text{ мА}; P_D=1\text{ Вт}; h_{21} > 100; f_T > 125\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AA	BCX51	PHIL	pnp	$V_{CB0}=45\text{ В}; I_C=1\text{ А}; P_D=1\text{ Вт}; h_{21}=40...250; f_T=50\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AA	BCX51	SIEM	pnp	$V_{CB0}=45\text{ В}; I_C=1\text{ А}; P_D=1\text{ Вт}; h_{21}=40...250; f_T=125\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AB	BCX516	PHIL	pnp	$V_{CB0}=45\text{ В}; I_C=1\text{ А}; P_D=1\text{ Вт}; h_{21}=40...100; f_T=125\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AC	2SA1690	ROHM	pnp	$V_{CB0}=400\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=2\text{ Вт}; h_{21}=56...270$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AC	BCX51-10	PHIL	pnp	$V_{CB0}=45\text{ В}; I_C=1\text{ А}; P_D=1\text{ Вт}; h_{21}=63...160; f_T=50\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AC	BCX51-10	SIEM	pnp	$V_{CB0}=45\text{ В}; I_C=1\text{ А}; P_D=1\text{ Вт}; h_{21}=63...160; f_T=125\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AD	BCX5116	PHIL	pnp	$V_{CB0}=45\text{ В}; I_C=1\text{ А}; P_D=1\text{ Вт}; h_{21}=100...250; f_T=50\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AD	BCX5116	SIEM	pnp	$V_{CB0}=45\text{ В}; I_C=1\text{ А}; P_D=1\text{ Вт}; h_{21}=100...250; f_T=125\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AE	BCX52	PHIL	pnp	$V_{CB0}=60\text{ В}; I_C=1\text{ А}; P_D=1\text{ Вт}; h_{21}=40...250; f_T=50\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AE	BCX52	SIEM	pnp	$V_{CB0}=60\text{ В}; I_C=1\text{ А}; P_D=1\text{ Вт}; h_{21}=40...250; f_T=125\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AEP	2SB1424	ROHM	pnp	$V_{CB0}=20\text{ В}; I_C=3\text{ А}; P_D=500\text{ мВт}; h_{21}=82...180; f_T > 240\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AEQ	2SB1424	ROHM	pnp	$V_{CB0}=20\text{ В}; I_C=3\text{ А}; P_D=500\text{ мВт}; h_{21}=120...270; f_T > 240\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AER	2SB1424	ROHM	pnp	$V_{CB0}=20\text{ В}; I_C=3\text{ А}; P_D=500\text{ мВт}; h_{21}=180...390; f_T > 240\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AF	2SA1575	SANYO	pnp	$V_{CB0}=200\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=500\text{ мВт}; h_{21}=40...320; f_T=400\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AF	BCX5206	PHIL	pnp	$V_{CB0}=60\text{ В}; I_C=1\text{ А}; h_{21}=40...100; f_T=125\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AF	BCX526	SIEM	pnp	$V_{CB0}=60\text{ В}; I_C=1\text{ А}; P_D=1\text{ Вт}; h_{21}=40...100; f_T=125\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AG	BCX5210	PHIL	pnp	$V_{CB0}=60\text{ В}; I_C=1\text{ А}; P_D=1\text{ Вт}; h_{21}=63...160; f_T=50\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AG	BCX5210	SIEM	pnp	$V_{CB0}=60\text{ В}; I_C=1\text{ А}; P_D=1\text{ Вт}; h_{21}=63...160; f_T=125\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AGP	2SA1797	ROHM	pnp	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=2\text{ А}; P_D=500\text{ мВт}; h_{21}=82...180; f_T > 200\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AGQ	2SA1797	ROHM	pnp	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=2\text{ А}; P_D=500\text{ мВт}; h_{21}=120...270; f_T > 200\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AH	BCP53	ON	pnp	$V_{CB0}=80\text{ В}; I_C=1.5\text{ А}; P_D=1.5\text{ Вт}; h_{21}=40...250; f_T=50\text{ МГц}$	SOT-223, TO-261AA	E • C • B • C
AH	BCX53	PHIL	pnp	$V_{CB0}=100\text{ В}; I_C=1\text{ А}; P_D=1\text{ Вт}; h_{21}=40...250; f_T=50\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AH	BCX53	SIEM	pnp	$V_{CB0}=80\text{ В}; I_C=1\text{ А}; P_D=1\text{ Вт}; h_{21}=40...250; f_T=125\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
AH-10	BCP53-10	ON	pnp	$V_{CB0}=80\text{ В}; I_C=1.5\text{ А}; P_D=1.5\text{ Вт}; h_{21}=63...160; f_T=50\text{ МГц}$	SOT-223, TO-261AA	E • C • B • C
AH-16	BCP53-16	ON	pnp	$V_{CB0}=80\text{ В}; I_C=1.5\text{ А}; P_D=1.5\text{ Вт}; h_{21}=100...250; f_T=50\text{ МГц}$	SOT-223, TO-261AA	E • C • B • C

**SOT89
SC62****SOT223
TO261A****TO252
DPAK****TO263
D2PAK**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4
AHN	2SA1759	ROHM	npn	$V_{CB0} = 400 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 12 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AHP	2SA1759	ROHM	npn	$V_{CB0} = 400 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 12 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AHQ	2SA1759	ROHM	npn	$V_{CB0} = 400 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 12 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AHQ	2SD2098	ROHM	npn	$V_{CB0} = 50 В; I_C = 5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AHR	2SD2098	ROHM	npn	$V_{CB0} = 50 В; I_C = 5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AHS	2SD2098	ROHM	npn	$V_{CB0} = 50 В; I_C = 5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 270...560; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AJ	BCX536	PHIL	npn	$V_{CB0} = 100 В; I_C = 1 А; h_{21} = 40...100; f_T = 50 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AJ	BCX536	SIEM	npn	$V_{CB0} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...100; f_T = 125 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AJN	2SA1812	ROHM	npn	$V_{CB0} = 400 В; I_C = 500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 12 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AJP	2SA1812	ROHM	npn	$V_{CB0} = 400 В; I_C = 500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 12 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AJQ	2SA1812	ROHM	npn	$V_{CB0} = 400 В; I_C = 500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 12 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AK	BCX5310	PHIL	npn	$V_{CB0} = 100 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 63...160; f_T = 50 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AK	BCX5310	SIEM	npn	$V_{CB0} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 63...160; f_T = 125 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AL	BCX5316	PHIL	npn	$V_{CB0} = 100 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 50 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AL	BCX5316	SIEM	npn	$V_{CB0} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 125 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
ALP	2SA1900	ROHM	npn	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
ALQ	2SA1900	ROHM	npn	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
ALR	2SA1900	ROHM	npn	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AM	BCX5216	PHIL	npn	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 50 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AM	BCX5216	SIEM	npn	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 125 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AQ	2SB766Q	PAN	npn	$V_{CB0} = 30 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85...170; f_T = 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AR	2SB766R	PAN	npn	$V_{CB0} = 30 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 120...240; f_T = 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AR	2SC3338	REN	npn	$V_{CB0} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 400 мВт; P_D = 8.3 дБ; f_T > 3.5 ГГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AR1	BSR40	PHIL	npn	$V_{CB0} = 70 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...120; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AR2	BSR41	PHIL	npn	$V_{CB0} = 70 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 100$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AR3	BSR42	PHIL	npn	$V_{CB0} = 90 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...120; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AR4	BSR43	PHIL	npn	$V_{CB0} = 90 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AS	2SB766S	PAN	npn	$V_{CB0} = 30 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 170...340; f_T = 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AS1	BST50	PHIL	dpnp	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AS1	BST50	MOT	dpnp	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AS1	BST50	ZETEX	dpnp	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AS2	BST51	PHIL	dpnp	$V_{CB0} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AS2	BST51	MOT	dpnp	$V_{CB0} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AS2	BST51	ZETEX	dpnp	$V_{CB0} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AS3	BSP52	ON	dpnp	$V_{CB0} = 90 В; I_C = 800 мА; P_D = 800 мВт; h_{21} > 2000$	SOT-223, TO-261AA	В•С•Е•С
AS3	BST52	PHIL	dpnp	$V_{CB0} = 90 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AS3	BST52	MOT	dpnp	$V_{CB0} = 90 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AS3	BST52	ZETEX	dpnp	$V_{CB0} = 90 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AT	2SD1470	REN	dpnp	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 2000...100000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AT1	BST39	PHIL	npn	$V_{CB0} = 400 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 70 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AT1	BST39	ZETEX	npn	$V_{CB0} = 400 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 70 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AT2	BST40	PHIL	npn	$V_{CB0} = 300 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 70 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
AT2	BST40	ZETEX	npn	$V_{CB0} = 300 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 70 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
ATN	2SA1812	ROHM	npn	$V_{CB0} = 400 В; I_C = 500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 12 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
ATP	2SA1812	ROHM	npn	$V_{CB0} = 400 В; I_C = 500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 12 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
ATQ	2SA1812	ROHM	npn	$V_{CB0} = 400 В; I_C = 500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 12 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BA	2SD1367A	REN	npn	$V_{CB0} = 20 В; I_C = 2 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BA	BCX54	PHIL	npn	$V_{CB0} = 45 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...250; f_T = 130 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BA	BCX54	SIEM	npn	$V_{CB0} = 45 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...250; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BAP	2SB1132	ROHM	npn	$V_{CB0} = 40 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С

**TO263
D2PAK**



**TO252
DPAK**



**SOT223
TO261A**



**SOT89
SC62**



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4
BAQ	2SB1132	ROHM	npn	$V_{CB0} = 40 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 120 \dots 270; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BAR	2SB1132	ROHM	npn	$V_{CB0} = 40 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 180 \dots 390; f_T > 150 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BB	2SD1367B	REN	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 2 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 160 \dots 320; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BB	BCX546	PHIL	npn	$V_{CB0} = 45 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 40 \dots 100; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BB	BCX546	SIEM	npn	$V_{CB0} = 45 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 40 \dots 100; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BC	2SD1367C	REN	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 2 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 250 \dots 500; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BC	BCX5410	PHIL	npn	$V_{CB0} = 45 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 63 \dots 160; f_T = 130 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BC	BCX5410	SIEM	npn	$V_{CB0} = 45 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 63 \dots 160; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BCP	2SB1188	ROHM	npn	$V_{CB0} = 40 \text{ В}; I_C = 2 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 82 \dots 180; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BCC	2SB1188	ROHM	npn	$V_{CB0} = 40 \text{ В}; I_C = 2 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 120 \dots 270; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BQC	2SB1188	ROHM	npn	$V_{CB0} = 40 \text{ В}; I_C = 2 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 180 \dots 390; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BD	BCX5416	PHIL	npn	$V_{CB0} = 45 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 100 \dots 250; f_T = 130 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BD	BCX5416	SIEM	npn	$V_{CB0} = 45 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 100 \dots 250; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BDP	2SB1189	ROHM	npn	$V_{CB0} = 80 \text{ В}; I_C = 700 \text{ мА}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 82 \dots 180; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BDQ	2SB1189	ROHM	npn	$V_{CB0} = 80 \text{ В}; I_C = 700 \text{ мА}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 120 \dots 270; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BDR	2SB1189	ROHM	npn	$V_{CB0} = 80 \text{ В}; I_C = 700 \text{ мА}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 180 \dots 390; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BE	BCX55	PHIL	npn	$V_{CB0} = 60 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 40 \dots 250; f_T = 130 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BE	BCX55	SIEM	npn	$V_{CB0} = 60 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 40 \dots 250; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BE	2SB1260	ROHM	npn	$V_{CB0} = 80 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 2 \text{ Вт}; h_{21} = 82 \dots 390; f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BF	BCX5506	SIEM	npn	$V_{CB0} = 60 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 40 \dots 100; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BF	BCX556	PHIL	npn	$V_{CB0} = 60 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 40 \dots 100; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BFP	2SB1308	ROHM	npn	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 3 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 82 \dots 180; f_T > 120 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BFQ	2SB1308	ROHM	npn	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 3 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 120 \dots 270; f_T > 120 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BFR	2SB1308	ROHM	npn	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 3 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 180 \dots 390; f_T > 120 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BG	BCX5510	PHIL	npn	$V_{CB0} = 60 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 63 \dots 160; f_T = 130 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BG	BCX5510	SIEM	npn	$V_{CB0} = 60 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 63 \dots 160; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BGR	2SB1124R	SANYO	npn	$V_{CB0} = 60 \text{ В}; I_C = 3 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 100 \dots 200; f_T = 150 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BGU	2SB1124R	SANYO	npn	$V_{CB0} = 60 \text{ В}; I_C = 3 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 280 \dots 560; f_T = 150 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BGH	2SB1001BH	REN	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 2 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 100 \dots 200; f_T = 150 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BH	2SB1125	SANYO	dnpnp	$V_{CB0} = 80 \text{ В}; I_C = 700 \text{ мА}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} > 5000; f_T = 200 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BH	BCP56	ON	npn	$V_{CB0} = 80 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1.5 \text{ Вт}; h_{21} = 40 \dots 250; f_T = 130 \text{ МГц}$	SOT-223, TO-261AA	Е•С•В•С
BH	BCX56	PHIL	npn	$V_{CB0} = 100 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 40 \dots 250; f_T = 130 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BH	BCX56	SIEM	npn	$V_{CB0} = 80 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 40 \dots 250; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BH-10	BCP56-10	ON	npn	$V_{CB0} = 80 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1.5 \text{ Вт}; h_{21} = 63 \dots 160; f_T = 130 \text{ МГц}$	SOT-223, TO-261AA	Е•С•В•С
BH-16	BCP56-16	ON	npn	$V_{CB0} = 80 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1.5 \text{ Вт}; h_{21} = 100 \dots 250; f_T = 130 \text{ МГц}$	SOT-223, TO-261AA	Е•С•В•С
BHP	2SB1386	ROHM	npn	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 5 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 82 \dots 180; f_T > 120 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BHQ	2SB1386	ROHM	npn	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 5 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 120 \dots 270; f_T > 120 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BHR	2SB1386	ROHM	npn	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 5 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 180 \dots 390; f_T > 120 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BI	2SB1126	SANYO	dnpnp	$V_{CB0} = 80 \text{ В}; I_C = 1.5 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} > 4000; f_T = 120 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BJ	2SB1001BJ	REN	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 2 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 160 \dots 320; f_T = 150 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BJ	BCX5606	SIEM	npn	$V_{CB0} = 80 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 40 \dots 100; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BJ	BCX566	PHIL	npn	$V_{CB0} = 80 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 40 \dots 100; f_T = 50 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BJE	2SB1427	ROHM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 2 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 390 \dots 820; f_T > 90 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BJS	2SB1427	ROHM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 2 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 270 \dots 560; f_T > 90 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BJU	2SB1427	ROHM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 2 \text{ А}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} = 560 \dots 1200; f_T > 90 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BK	BCX5610	PHIL	npn	$V_{CB0} = 100 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 63 \dots 160; f_T = 130 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BK	BCX5610	SIEM	npn	$V_{CB0} = 80 \text{ В}; I_C = 1 \text{ А}; P_D = 1 \text{ Вт}; h_{21} = 63 \dots 160; f_T = 100 \text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С

**SOT89
SC62****SOT223
TO261A****TO252
DPAK****TO263
D2PAK**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4
BL	BCX5616	PHIL	npn	$V_{CBO} = 100 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 130 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BL	BCX5616	SIEM	npn	$V_{CBO} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BLP	2SB1561	ROHM	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BLQ	2SB1561	ROHM	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BM	BCX5516	PHIL	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 130 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BM	BCX5516	SIEM	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BO	2SA1200	TOSH	npn	$V_{CBO} = 150 В; I_C = 50 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 70...140; f_T > 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BO	KTA1660	KEC	npn	$V_{CBO} = 150 В; I_C = 50 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 70...140; f_T > 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BQ	2SB766AQ	PAN	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85...170; f_T = 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BR	2SB766AR	PAN	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 120...240; f_T = 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BR1	BSR30	PHIL	npn	$V_{CBO} = 70 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...120; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BR2	BSR31	PHIL	npn	$V_{CBO} = 70 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BR3	BSR32	PHIL	npn	$V_{CBO} = 90 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...120; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BR4	BSR33	PHIL	npn	$V_{CBO} = 90 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BS	2SB766AS	PAN	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 170...340; f_T = 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BS1	BST60	PHIL	dpnp	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BS1	BST60	MOT	dpnp	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BS1	BST60	ZETEX	dpnp	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BS2	BST61	PHIL	dpnp	$V_{CBO} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BS2	BST61	MOT	dpnp	$V_{CBO} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BS2	BST61	ZETEX	dpnp	$V_{CBO} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BS3	BSP62	ON	dpnp	$V_{CBO} = 90 В; I_C = 1 А; P_D = 1.25 Вт; h_{21} > 2000; f_T = 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BS3	BST62	PHIL	dpnp	$V_{CBO} = 90 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BS3	BST62	MOT	dpnp	$V_{CBO} = 90 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BS3	BST62	ZETEX	dpnp	$V_{CBO} = 90 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BT	2SB1048	REN	dpnp	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 2000...100000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BT1	BST15	PHIL	npn	$V_{CBO} = 200 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 30...150; f_T > 15 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BT2	BSP16	ON	npn	$V_{CBO} = 350 В; I_C = 200 мА; P_D = 1.28 Вт; h_{21} > 30; f_T > 15 МГц$	SOT-223, TO-261AA	В•С•Е•С
BT2	BST16	PHIL	npn	$V_{CBO} = 350 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 30...120; f_T > 15 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BY	2SA1200	TOSH	npn	$V_{CBO} = 150 В; I_C = 50 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...240; f_T > 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BY	KTA1660	KEC	npn	$V_{CBO} = 150 В; I_C = 50 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...240; f_T > 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
BYR210	PBYR2100CT	PHIL	shd x2	$V_A < 100 В; V_F (I_F = 1 А) < 0.69 В; C_T < 100 нФ$	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
BYR215	PBYR2150CT	PHIL	shd x2	$V_A < 150 В; V_F (I_F = 1 А) < 0.69 В; C_T < 100 нФ$	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
BYR220	PBYR220CT	PHIL	shd x2	$V_A < 20 В; V_F (I_F = 2 А) < 0.51 В; C_T = 160 нФ$	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
BYR225	PBYR225CT	PHIL	shd x2	$V_A < 25 В; V_F (I_F = 2 А) < 0.51 В; C_T = 160 нФ$	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
BYR240	PBYR240CT	PHIL	shd x2	$V_A < 40 В; V_F (I_F = 2 А) < 0.7 В; C_T = 60 нФ$	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
BYR245	PBYR245CT	PHIL	shd x2	$V_A < 45 В; V_F (I_F = 2 А) < 0.7 В; C_T = 60 нФ$	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
BYR28	PBYR280CT	PHIL	shd x2	$V_A < 80 В; V_F (I_F = 1 А) < 0.69 В; C_T < 100 нФ$	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
BYR29	PBYR290CT	PHIL	shd x2	$V_A < 90 В; V_F (I_F = 1 А) < 0.69 В; C_T < 100 нФ$	SOT-223, TO-261AA	A1•K1, K2•A2•K1, K2
CA	BCP68	MOT	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 1 А; P_D = 1.5 Вт; h_{21} = 85...375; f_T = 60 МГц$	SOT-223, TO-261AA	Е•С•В•С
CAC	BC868	PHIL	npn	$V_{CBO} = 25 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85...375; f_T > 40 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CB	2SD1368	REN	npn	$V_{CBO} = 100 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160...320; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CB	BCX6810	SIEM	npn	$V_{CBO} = 20 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85...160; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С

**TO263
D2PAK**



**TO252
DPAK**



**SOT223
TO261A**



**SOT89
SC62**



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4
CBC	BC86810	PHIL	nprn	$V_{CB0} = 25 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160...500; f_T > 40 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CBN	2SC4132	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 120 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 80 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CBP	2SC4132	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 120 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 80 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CBQ	2SC4132	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 120 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 80 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CBR	2SC4132	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 120 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 80 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CC	2SD1368	REN	nprn	$V_{CB0} = 100 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 250...500; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CCC	BCX6816	SIEM	nprn	$V_{CB0} = 20 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CCD	BC86816	PHIL	nprn	$V_{CB0} = 25 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T > 40 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CCS	BCP69	MOT	pnnp	$V_{CB0} = 20 В; I_C = 1 А; P_D = 1.5 Вт; h_{21} = 85...375; f_T = 60 МГц$	SOT-223, TO-261AA	Е•С•В•С
CEC	BC869	PHIL	pnnp	$V_{CB0} = 25 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85...375; f_T > 40 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CEN	2SC4505	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 400 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 20 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CEP	2SC4505	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 400 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 20 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CEQ	2SC4505	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 400 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 20 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CF	BCX6910	SIEM	pnnp	$V_{CB0} = 20 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85...160; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CFC	BC86910	PHIL	pnnp	$V_{CB0} = 25 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} > 160; f_T > 40 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CFQ	2SD2150	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 40 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 290 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CFR	2SD2150	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 40 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 290 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CFS	2SD2150	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 40 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 270...560; f_T > 290 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CG	BCX6916	SIEM	pnnp	$V_{CB0} = 20 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CGC	BC86916	PHIL	nprn	$V_{CB0} = 25 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...250; f_T > 40 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CGP	2SC5053	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CGQ	2SC5053	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CGR	2SC5053	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CH	2SB1002CH	REN	pnnp	$V_{CB0} = 70 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200; f_T = 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CHC	BCX6925	SIEM	pnnp	$V_{CB0} = 20 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160...375; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CHI	BC86925	PHIL	nprn	$V_{CB0} = 25 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160; f_T > 40 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CI	2SC4080	SANYO	nprn	$V_{CB0} = 200 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 40...320; f_T = 400 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CJ	2SB1002CJ	REN	pnnp	$V_{CB0} = 70 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160...320; f_T = 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CR	2SC4422	REN	nprn	$V_{CB0} = 15 В; I_C = 50 мА; P_D = 400 мВт; h_{21} = 50250; f_T > 4.5 ГГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
CT	2SD1472	REN	dnprn	$V_{CB0} = 120 В; I_C = 1.5 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 2000...3000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DA	2SD1418	REN	nprn	$V_{CB0} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 60...120; f_T = 140 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DA	BF622	PHIL	nprn	$V_{CB0} = 250 В; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 50; f_T > 60 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DA	BF622	SIEM	nprn	$V_{CB0} = 250 В; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 50; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DAP	2SD1664	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 40 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DAR	2SD1664	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 40 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DAS	2SD1664	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 40 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DB	2SD1418	REN	nprn	$V_{CB0} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200; f_T = 140 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DB	BF623	PHIL	pnnp	$V_{CB0} = 250 В; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 50; f_T > 60 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DB	BF623	SIEM	pnnp	$V_{CB0} = 250 В; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 50; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DBP	2SD1766	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 40 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DBQ	2SD1766	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 40 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DBR	2SD1766	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 40 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DC	2SD1418	REN	nprn	$V_{CB0} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160...320; f_T = 140 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DC	BF620	PHIL	nprn	$V_{CB0} = 300 В; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 50; f_T > 60 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DC	BF720T1	ON	nprn	$V_{CB0} = 300 В; I_C = 100 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} > 50; f_T > 60 МГц$	SOT-223, TO-261AA	В•С•Е•С
DC	BFN20	SIEM	nprn	$V_{CB0} = 300 В; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DCP	2SD1767	ROHM	nprn	$V_{CB0} = 80 В; I_C = 700 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С

**SOT89
SC62****SOT223
TO261A****TO252
DPAK****TO263
D2PAK**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4
DCQ	2SD1767	ROHM	npn	$V_{CBO} = 80 В; I_C = 700 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DCR	2SD1767	ROHM	npn	$V_{CBO} = 80 В; I_C = 700 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DD	2SD1419	REN	npn	$V_{CBO} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 60...120; f_T = 140 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DD	BFN16	SIEM	npn	$V_{CBO} = 250 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 70 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DDP	2SD1766	ROHM	npn	$V_{CBO} = 40 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DDQ	2SD1766	ROHM	npn	$V_{CBO} = 40 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DDR	2SD1766	ROHM	npn	$V_{CBO} = 40 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DE	2SD1419	REN	npn	$V_{CBO} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200; f_T = 140 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DE	2SD1834	ROHM	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 2000$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DE	BFN18	SIEM	npn	$V_{CBO} = 300 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 30; f_T > 70 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DF	2SD1898	ROHM	npn	$V_{CBO} = 80 В; I_C = 1 А; P_D = 2 Вт; h_{21} = 82...390; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DF	BF621	PHIL	pmc	$V_{CBO} = 300 В; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 50; f_T > 60 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DF	BF721T1	ON	pmc	$V_{CB} = 300 В; I_C = 100 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} > 50; f_T = 60 МГц$	SOT-223, TO-261AA	В•С•Е•С
DF	BFN21	SIEM	pmc	$V_{CBO} = 300 В; I_C = 50 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DG	BFN17	SIEM	pmc	$V_{CBO} = 250 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DGQ	2SD1963	ROHM	npn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DGR	2SD1624R	SANYO	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 100...200; f_T = 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DGR	2SD1963	ROHM	npn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DGS	2SD1624S	SANYO	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 140...280; f_T = 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DGS	2SD1963	ROHM	npn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 270...560; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DGT	2SD1624T	SANYO	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 200...400; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DGU	2SD1624U	SANYO	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 280...560; f_T = 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DH	2SB1025DH	REN	pmc	$V_{CBO} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 60...120; f_T = 140 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DH	2SD1625	SANYO	dmnp	$V_{CBO} = 80 В; I_C = 700 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 5000; f_T > 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DH	BFN19	SIEM	pmc	$V_{CBO} = 300 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 30; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DI	2SD1626	SANYO	dmnp	$V_{CBO} = 80 В; I_C = 1.5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 4000; f_T = 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DJ	2SB1025DJ	REN	pmc	$V_{CBO} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200; f_T = 140 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DJQ	2SD2098	ROHM	npn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DJR	2SD2098	ROHM	npn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 180...390; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DJS	2SD2098	ROHM	npn	$V_{CBO} = 50 В; I_C = 5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 270...560; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DK	2SB1025DK	REN	pmc	$V_{CBO} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 160...320; f_T = 140 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DKP	2SC4672	ROHM	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 210 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DKQ	2SC4672	ROHM	npn	$V_{CBO} = 60 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 210 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DL	2SB1026DL	REN	pmc	$V_{CBO} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 60...120; f_T = 140 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DLN	2SD2167	ROHM	npn	$V_{CBO} = 31 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DLP	2SD2167	ROHM	npn	$V_{CBO} = 31 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DLO	2SD2167	ROHM	npn	$V_{CBO} = 31 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DM	2SB1026DM	REN	pmc	$V_{CBO} = 120 В; I_C = 1 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200; f_T = 140 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DM	2SD2170	ROHM	npn	$V_{CBO} = 90 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 1000...10000; f_T > 80 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DNE	2SD2153	ROHM	npn	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 390...820; f_T > 110 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DNU	2SD2153	ROHM	npn	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 560...1200; f_T > 110 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DNV	2SD2153	ROHM	npn	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 820...1800; f_T > 110 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DNW	2SD2153	ROHM	npn	$V_{CBO} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 1200...2700; f_T > 110 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DO	2SA1201	TOSH	pmc	$V_{CBO} = 120 В; I_C = 800 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 70...140; f_T = 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DP	2SD2195	ROHM	npn	$V_{CBO} = 100 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 1000...10000; f_T > 80 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DQN	2SD2211	ROHM	npn	$V_{CBO} = 160 В; I_C = 1500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 56...120; f_T > 80 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DQP	2SD2211	ROHM	npn	$V_{CBO} = 160 В; I_C = 1500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 80 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DQQ	2SD2211	ROHM	npn	$V_{CBO} = 160 В; I_C = 1500 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 80 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С

**TO263
D2PAK**



**TO252
DPAK**



**SOT223
TO261A**



**SOT89
SC62**



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4
DR	2SC4643	REN	npn	$V_{CB0} = 15 В; I_C = 50 мА; P_D = 400 мВт; h_{21} = 40250; f_T > 5.5 ГГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DR	2SD2212	ROHM	npn	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 1000...10000; f_T > 80 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DTP	2SD2391	ROHM	npn	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 82...180; f_T > 210 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DTQ	2SD2391	ROHM	npn	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 120...270; f_T > 210 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
DY	2SA1201	TOSH	pnp	$V_{CB0} = 120 В; I_C = 800 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...240; f_T = 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
E01	DTDG14EP	ROHM	Dnpn+dz	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 300; f_T > 80 МГц; P_T = 10 КОМ$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
E01	DTDG14GP	ROHM	Dnpn+dz	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 300; f_T > 80 МГц; P_T = 10 КОМ$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
E02	DTDG23VP	ROHM	Dnpn+dz	$V_{CB0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 1.5 Вт; h_{21} > 300; f_T = 80 МГц; 2.2 к/10 к$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
ED	2SD1421	REN	npn	$V_{CB0} = 180 В; I_C = 1.5 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 60...120$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
ED	BCV28	INF	dnpn	$V_{CB0} = 40 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 100; f_T = 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
EE	2SD1421	REN	npn	$V_{CB0} = 180 В; I_C = 1.5 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
EE	BCV48	INF	dnpn	$V_{CB0} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 400; f_T = 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
EF	BCV29	INF	dnpn	$V_{CB0} = 40 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 100; f_T = 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
EG	BCV49	INF	dnpn	$V_{CB0} = 80 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 400; f_T = 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
EL	2SB1028EL	REN	pnp	$V_{CB0} = 180 В; I_C = 1.5 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 60...120$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
EM	2SB1028EM	REN	pnp	$V_{CB0} = 180 В; I_C = 1.5 А; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
ER	2SC4807	REN	npn	$V_{CB0} = 20 В; I_C = 200 мА; P_D = 800 мВт; h_{21} = 50...250; f_T > 3 ГГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
FA	BFQ17	PHIL	npn	$V_{CB0} = 40 В; I_C = 300 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85; f_T = 1.5 ГГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
FB	BFQ19	PHIL	npn	$V_{CB0} = 15 В; I_C = 100 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 25; f_T = 5.5 ГГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
FC	BFQ64	SIEM	npn	$I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 25; f_T > 3 ГГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
FD	BFQ17P	SIEM	npn	$V_{CB0} = 40 В; I_C = 300 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 85; f_T = 1.5 ГГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
FEs	BFQ19P	SIEM	npn	$V_{CB0} = 15 В; I_C = 100 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 25; f_T = 5.5 ГГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
FF	BFQ18A	PHIL	npn	$V_{CB0} = 25 В; I_C = 150 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 25; f_T = 4 ГГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
FGs	BFQ19S	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20 В; I_C = 75 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 40...220; f_T = 5500 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
FO	2SA1202	TOSH	pnp	$V_{CB0} = 80 В; I_C = 400 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 70...140; f_T = 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
FY	2SA1202	TOSH	pnp	$V_{CB0} = 80 В; I_C = 400 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...240; f_T = 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
GA	BAW78A	SIEM	di	$V_R < 50 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.6 В; I_S < 1.0 мА; C_D < 10 пФ; t_{RR} < 1000 нс$	SOT-89, SC-62	А•К•н.с.с К
GB	BAW78B	SIEM	di	$V_R < 100 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.6 В; I_S < 1.0 мА; C_D < 10 пФ; t_{RR} < 1000 нс$	SOT-89, SC-62	А•К•н.с.с К
GC	BAW78C	SIEM	di	$V_R < 200 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.6 В; I_S < 1.0 мА; C_D < 10 пФ; t_{RR} < 1000 нс$	SOT-89, SC-62	А•К•н.с.с К
GD	BAW78D	SIEM	di	$V_R < 400 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.6 В; I_S < 1.0 мА; C_D < 10 пФ; t_{RR} < 1000 нс$	SOT-89, SC-62	А•К•н.с.с К
GE	BAW79A	SIEM	di x2	$V_R < 50 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.6 В; I_S < 1.0 мА; C_D < 10 пФ; t_{RR} < 1000 нс$	SOT-89, SC-62	А1•К1, К2• А2•К1, К2
GF	BAW79B	SIEM	di x2	$V_R < 100 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.6 В; I_S < 1.0 мА; C_D < 10 пФ; t_{RR} < 1000 нс$	SOT-89, SC-62	А1•К1, К2• А2•К1, К2
GG	BAW79C	SIEM	di x2	$V_R < 200 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.6 В; I_S < 1.0 мА; C_D < 10 пФ; t_{RR} < 1000 нс$	SOT-89, SC-62	А1•К1, К2• А2•К1, К2
GH	BAW79D	SIEM	di x2	$V_R < 400 В; I_F < 1 А; V_F (I_F = 1 А) < 1.6 В; I_S < 1.0 мА; C_D < 10 пФ; t_{RR} < 1000 нс$	SOT-89, SC-62	А1•К1, К2• А2•К1, К2
GO	KTC4375	KEC	npn	$V_{CB0} = 30 В; I_C = 1.5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 100...200; f_T > 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
GY	KTC4375	KEC	npn	$V_{CB0} = 30 В; I_C = 1.5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 160...320; f_T > 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
HO	2SA1203	TOSH	pnp	$V_{CB0} = 30 В; I_C = 1.5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 100...200; f_T = 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
HO	KTA1663	KEC	pnp	$V_{CB0} = 30 В; I_C = 1.5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 100...200; f_T > 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
HY	2SA1203	TOSH	pnp	$V_{CB0} = 30 В; I_C = 1.5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 160...320; f_T = 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
HY	KTA1663	KEC	pnp	$V_{CB0} = 30 В; I_C = 1.5 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 160...320; f_T > 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С

**SOT89
SC62****SOT223
TO261A****TO252
DPAK****TO263
D2PAK**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4
JO	2SA1384	TOSH	npn	$V_{CE0} = 300 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 50...150; f_T > 50 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
JR	2SA1384	TOSH	npn	$V_{CE0} = 300 В; I_C = 100 мА; P_D = 500 мВт; h_{21} > 30...90; f_T > 50 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
JR	2SC5631	REN	npn	$V_{CE0} = 15 В; I_C = 80 мА; P_D = 800 мВт; h_{21} > 80...160; f_T > 8 ГГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
JX	2SK3391	REN	nMOS	$V_{GS} = 17 В; I_D = 300 мА; P_D = 5 Вт$	SOT-89, SC-62	Г•S•D•S
KO	BST86	PHIL	nMOS	$V_{GS} = 180 В; I_D = 300 мА; P_D = 1 Вт; R_{DS(on)} = 7 Ом$	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
KA	2SC4409	PHIL	npn	$V_{CE0} = 80 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...400; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
KA	BSS87	SIEM	nMOS	$V_{GS} = 240 В; I_D = 290 мА; P_D = 1 Вт; g_m = 50 мС; R_{DS} = 10 Ом$	SOT-89, SC-62	Г•D•S•D
KB	2SC4539	TOSH	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 1.2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...400; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
KB	BSS192	INF	pMOS	$V_{GS} = 240 В; I_D = 150 мА; P_D = 1 Вт; g_m = 120 мС; R_{DS} = 3.5 Ом$	SOT-89, SC-62	Г•D•S•D
KC	2SC4540	TOSH	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...400; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
KD	2SC4541	TOSH	npn	$V_{CE0} = 50 В; I_C = 3 А; P_D = 1500 мВт; h_{21} > 120...400; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
KM	BST80	PHIL	nMOS	$V_{GS} = 80 В; I_D = 500 мА; P_D = 1 Вт; R_{DS(on)} = 3 Ом$	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
KM	BST80	ZETEX	nMOS	$V_{GS} = 80 В; I_D = 500 мА; P_D = 1 Вт; R_{DS(on)} = 3 Ом$	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
KN	BST84	PHIL	nMOS	$V_{GS} = 200 В; I_D = 250 мА; P_D = 1 Вт; R_{DS(on)} = 6 Ом$	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
LA	2SC1681	TOSH	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...400; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
LA	KTD1003	KEC	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 1.0 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 800...1600; f_T = 250 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
LB	2SC1734	TOSH	prnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 1.2 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...400; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
LB	KTD1003	KEC	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 1.0 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 1200...2400; f_T > 250 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
LC	2SC1735	TOSH	prnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 1 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...400; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
LC	KTD1003	KEC	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 1.0 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 2000...3200; f_T > 250 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
LD	2SC1736	TOSH	prnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 120...400; f_T = 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
LM	BST120	PHIL	pMOS	$V_{GS} = 60 В; I_D = 300 мА; P_D = 1 Вт; g_m = 200 мС; R_{DS(on)} = 4.5 Ом$	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
LN	BST122	PHIL	pMOS	$V_{GS} = 60 В; I_D = 250 мА; P_D = 1 Вт; g_m = 125 мС; R_{DS(on)} = 7.5 Ом$	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
LYD	2SC4003D	SANYO	npn	$V_{CE0} = 400 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 60...120; f_T = 70 МГц$	TO-252, DPAK	В•С•Е•С
LYE	2SC4003E	SANYO	npn	$V_{CE0} = 400 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...200; f_T = 70 МГц$	TO-252, DPAK	В•С•Е•С
NO1	DTDM122P	ROHM	drnpn+dz	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 3 А; P_D = 500 мВт; h_{21} > 68; f_T > 80 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
p1A	PXT3904	PHIL	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 300 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
p1B	PXT2222	PHIL	npn	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
p1D	PXTA42	PHIL	npn	$V_{CE0} = 300 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 50 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
p1D	PZTA42	MOT	npn	$V_{CE0} = 300 В; I_C = 500 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} > 25; f_T > 50 МГц$	SOT-223, TO-261AA	В•С•Е•С
p1E	PXTA43	PHIL	npn	$V_{CE0} = 200 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 50 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
p1F	PZT2222A	ON	npn	$V_{CE0} = 75 В; I_C = 600 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} = 50...300; f_T > 300 МГц$	SOT-223, TO-261AA	В•С•Е•С
p1M	PXTA13	PHIL	drnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 625 мВт; h_{21} > 5000; f_T > 125 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
p1N	PXTA14	PHIL	drnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 300 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 20000; f_T > 125 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
p1N	PZTA14	MOT	drnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 300 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT-223, TO-261AA	В•С•Е•С
p1P	PXT2222A	PHIL	npn	$V_{CE0} = 75 В; I_C = 600 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 300 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
p2A	PXT3906	PHIL	prnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
p2B	PXT2907	PHIL	prnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
p2D	PXTA92	PHIL	prnp	$V_{CE0} = 300 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 50 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
P2D	PZTA92	MOT	prnp	$V_{CE0} = 300 В; I_C = 500 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} > 25; f_T > 50 МГц$	SOT-223, TO-261AA	В•С•Е•С
p2E	PXTA93	PHIL	prnp	$V_{CE0} = 200 В; I_C = 500 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 40; f_T > 50 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
p2F	PXT2907A	PHIL	prnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
p2F	PZT2907A	ON	prnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 600 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT-223, TO-261AA	В•С•Е•С
p2T	PXT4403	PHIL	prnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 600 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
p2V	PXTA64	PHIL	prnp	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 300 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
P2V	PZTA64	MOT	drnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 500 мА; P_D = 1.5 Вт; h_{21} > 10000; f_T > 125 МГц$	SOT-223, TO-261AA	В•С•Е•С
p2X	PXT4401	PHIL	prnp	$V_{CE0} = 40 В; I_C = 600 мА; P_D = 1 Вт; h_{21} = 100...300; f_T > 250 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
PO	KTCA4376	KEC	npn	$V_{CE0} = 35 В; I_C = 0.8 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 100...200; f_T = 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
PY	KTCA4376	KEC	npn	$V_{CE0} = 35 В; I_C = 0.8 А; P_D = 500 мВт; h_{21} = 160...320; f_T = 120 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С

**TO263
D2PAK**



**TO252
DPAK**



**SOT223
TO261A**



**SOT89
SC62**



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4
R111718	REG1117A-1.8	TI	reg	LDO; I _{OUT} = 1 A; V _{OUT} = 1.8 В	SOT-223, TO-261AA	GND • VOUT • VIN • VOUT
R111725	REG1117A-2.5	TI	reg	LDO; I _{OUT} = 1 A; V _{OUT} = 2.5 В	SOT-223, TO-261AA	GND • VOUT • VIN • VOUT
RCs	BFQ193	SIEM	nprn	V _{CEB} = 20 В; I _C = 80 мА; P _D = 600 мВт; h ₂₁ = 50...200; f _T = 7500 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
RE	2SC3357E	NEC	nprn	V _{CEB} = 20 В; I _C = 100 мА; P _D = 1.2 Вт; h ₂₁ = 125...250; f _T = 6.5 ГГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
REG1117F A	REG1117FA	TI	reg	LDO; I _{OUT} = 1 A; V _{REF} = 1.25 В	TO-263, D2PAK	ADJ • VOUT • VIN • VOUT
REG1117F A1.8	REG1117FA- 1.8	TI	reg	LDO; I _{OUT} = 1 A; V _{OUT} = 1.8 В	TO-263, D2PAK	GND • VOUT • VIN • VOUT
REG1117F A2.5	REG1117FA- 2.5	TI	reg	LDO; I _{OUT} = 1 A; V _{OUT} = 2.5 В	TO-263, D2PAK	GND • VOUT • VIN • VOUT
REG1117F A5.0	REG1117FA-5	TI	reg	LDO; I _{OUT} = 1 A; V _{OUT} = 5 В	TO-263, D2PAK	GND • VOUT • VIN • VOUT
RF	2SC3357F	NEC	nprn	V _{CEB} = 20 В; I _C = 100 мА; P _D = 1.2 Вт; h ₂₁ = 80...160; f _T = 6.5 ГГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
RH	2SC3357H	NEC	nprn	V _{CEB} = 20 В; I _C = 100 мА; P _D = 1.2 Вт; h ₂₁ = 50...100; f _T = 6.5 ГГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
RO	2SA1204	TOSH	pnp	V _{CEB} = 95 В; I _C = 800 мА; P _D = 500 мВт; h ₂₁ > 100...200; f _T = 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
RO	KTA1664	KEC	pnp	V _{CEB} = 35 В; I _C = 0.8 А; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 100...200; f _T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
RY	2SA1204	TOSH	pnp	V _{CEB} = 95 В; I _C = 800 мА; P _D = 500 мВт; h ₂₁ > 160...320; f _T = 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
RY	KTA1664	KEC	pnp	V _{CEB} = 35 В; I _C = 0.8 А; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 160...320; f _T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SA	2SC2982	TOSH	nprn	V _{CEB} = 30 В; I _C = 2 А; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 140...240; f _T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SB	2SC2982	TOSH	nprn	V _{CEB} = 30 В; I _C = 2 А; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 200...330; f _T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SC	2SC2982	TOSH	nprn	V _{CEB} = 30 В; I _C = 2 А; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 300...450; f _T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SCO	KSC2881	SAMS	nprn	V _{CEB} = 120 В; I _C = 800 мА; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 80...160; f _T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SCY	KSC2881	SAMS	nprn	V _{CEB} = 120 В; I _C = 800 мА; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 120...240; f _T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SD	2SC2982	TOSH	nprn	V _{CEB} = 30 В; I _C = 2 А; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 420...600; f _T = 140 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SDO	KSA1201	SAMS	pnp	V _{CEB} = 120 В; I _C = 800 мА; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 80...160; f _T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SDO	KSA1203	SAMS	pnp	V _{CEB} = 30 В; I _C = 1.5 А; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 100...200; f _T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SDY	KSA1201	SAMS	pnp	V _{CEB} = 120 В; I _C = 800 мА; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 120...240; f _T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SDY	KSA1203	SAMS	pnp	V _{CEB} = 30 В; I _C = 1.5 А; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 160...320; f _T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SE	NE46234	NEC	nprn	CB4; NF = 2.3 дБ; h ₂₁ = 125...250	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SE	NE462M02	NEC	nprn	CB4; h ₂₁ = 125...250	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SF	NE46234	NEC	nprn	CB4; NF = 2.3 дБ; h ₂₁ = 80...160	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SF	NE462M02	NEC	nprn	CB4; h ₂₁ = 80...160	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SH	NE46234	NEC	nprn	CB4; NF = 2.3 дБ; h ₂₁ = 50...100	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SH	NE462M02	NEC	nprn	CB4; h ₂₁ = 50...100	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SHO	KSC2883	SAMS	nprn	V _{CEB} = 30 В; I _C = 1500 мА; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 100...200; f _T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SHY	KSC2883	SAMS	nprn	V _{CEB} = 30 В; I _C = 1500 мА; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 160...320; f _T > 120 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SLG	KSB798	SAMS	pnp	V _{CEB} = 30 В; I _C = 1 А; P _D = 2 Вт; h ₂₁ = 200...400; f _T > 110 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SLO	KSB798	SAMS	pnp	V _{CEB} = 30 В; I _C = 1 А; P _D = 2 Вт; h ₂₁ = 90...180; f _T > 110 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SLY	KSB798	SAMS	pnp	V _{CEB} = 30 В; I _C = 1 А; P _D = 2 Вт; h ₂₁ = 135...270; f _T > 110 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SSA	KSC2982	SAMS	nprn	V _{CEB} = 30 В; I _C = 2 А; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 140...240; f _T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SSB	KSC2982	SAMS	nprn	V _{CEB} = 30 В; I _C = 2 А; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 200...330; f _T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SSC	KSC2982	SAMS	nprn	V _{CEB} = 30 В; I _C = 2 А; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 300...450; f _T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SSD	KSC2982	SAMS	nprn	V _{CEB} = 30 В; I _C = 2 А; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 420...600; f _T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C
SYR	KSD1621	SAMS	nprn	V _{CEB} = 30 В; I _C = 2 А; P _D = 500 мВт; h ₂₁ = 100...200; f _T > 150 МГц	SOT-89, SC-62	B • C • E • C

**SOT89
SC62****SOT223
TO261A****TO252
DPAK****TO263
D2PAK**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4
SYS	KSD1621	SAMS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; I_{H1} = 140...280; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
SYT	KSD1621	SAMS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; I_{H1} = 200...400; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
SYU	KSD1621	SAMS	npn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; I_{H1} = 100...200; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
SZR	KSB1121	SAMS	pnnp	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; I_{H1} = 140...280; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
SZS	KSB1121	SAMS	pnnp	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; I_{H1} = 140...280; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
SZT	KSB1121	SAMS	pnnp	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; I_{H1} = 200...400; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
SZU	KSB1121	SAMS	pnnp	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; I_{H1} = 280...560; f_T > 150 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
T09A	MC33464N-09AT1	ON	mrc	$V_{FR} = 0.9 В; V_{IN} = 0.7...10 В$	SOT-89, SC-62	RESET • IN GND • IN
T09C	MC33464N-09CT1	ON	mrc	$V_{FR} = 0.9 В; V_{IN} = 0.7...10 В$	SOT-89, SC-62	RESET • IN GND • IN
T20A	MC33464N-20AT1	ON	mrc	$V_{FR} = 2.0 В; V_{IN} = 0.7...10 В$	SOT-89, SC-62	RESET • IN GND • IN
T20C	MC33464N-20CT1	ON	mrc	$V_{FR} = 2.0 В; V_{IN} = 0.7...10 В$	SOT-89, SC-62	RESET • IN GND • IN
T27A	MC33464N-27AT1	ON	mrc	$V_{FR} = 2.7 В; V_{IN} = 0.7...10 В$	SOT-89, SC-62	RESET • IN GND • IN
T27C	MC33464N-27CT1	ON	mrc	$V_{FR} = 2.7 В; V_{IN} = 0.7...10 В$	SOT-89, SC-62	RESET • IN GND • IN
T30A	MC33464N-30AT1	ON	mrc	$V_{FR} = 3.0 В; V_{IN} = 0.7...10 В$	SOT-89, SC-62	RESET • IN GND • IN
T30C	MC33464N-30CT1	ON	mrc	$V_{FR} = 3.0 В; V_{IN} = 0.7...10 В$	SOT-89, SC-62	RESET • IN GND • IN
T43C	MC33464N-43CT1	ON	mrc	$V_{FR} = 4.3 В; V_{IN} = 0.7...10 В$	SOT-89, SC-62	RESET • IN GND • IN
T45A	MC33464N-45AT1	ON	mrc	$V_{FR} = 4.5 В; V_{IN} = 0.7...10 В$	SOT-89, SC-62	RESET • IN GND • IN
T45C	MC33464N-45CT1	ON	mrc	$V_{FR} = 4.5 В; V_{IN} = 0.7...10 В$	SOT-89, SC-62	RESET • IN GND • IN
TA	2SA1314	TOSH	pnnp	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; I_{H1} > 140...280; f_T = 140 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
TB	2SA1314	TOSH	pnnp	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; I_{H1} > 200...400; f_T = 140 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
TC	2SA1314	TOSH	pnnp	$V_{CE0} = 20 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; I_{H1} > 300...600; f_T = 140 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
VD	1SV268	SANYO	pin	$V_R > 50 В; I_R < 100 мА; V_F (I_F = 100 мА) < 1 В; I_S < 0.5 мА$	SOT-89, SC-62	А•К•п.с.с К
VO	2SC3803	TOSH	npn	$V_{CE0} = 45 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; I_{H1} > 70...140; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
VR	2SC3803R	TOSH	npn	$V_{CE0} = 45 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; I_{H1} > 40...80; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
VY	2SC3803Y	TOSH	npn	$V_{CE0} = 45 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; I_{H1} > 140...280; f_T > 100 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
VY	2SC3803Y	TOSH	npn	$V_{CE0} = 45 В; I_C = 200 мА; P_D = 1 Вт; I_{H1} > 140...280; f_T > 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
W8	BZV49C3V9	ZETEX	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 3.7...4.1 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 90 Ом; I_{ZM} = 250 мА$	SOT-89, SC-62	А•К•А•К
W9	BZV49C4V3	ZETEX	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 4.0...4.6 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 90 Ом; I_{ZM} = 250 мА$	SOT-89, SC-62	А•К•А•К
W0	2SA14830	TOSH	pnnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 200 мА; P_D = 500 мВт; I_{H1} = 70...140; f_T = 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
WR	2SA1483R	TOSH	pnnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 200 мА; P_D = 500 мВт; I_{H1} = 40...80; f_T = 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
WY	2SA1483Y	TOSH	pnnp	$V_{CE0} = 60 В; I_C = 200 мА; P_D = 500 мВт; I_{H1} = 120...240; f_T = 200 МГц$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
WY	2SJ484	REN	pMOS	$V_{DS} = 30 В; I_D = 2 А; P_D = 1 Вт; R_{DS(on)} < 0.23 Ом$	SOT-89, SC-62	G•D•S•D
X2	BZV49C30	ZETEX	dz	$V_Z (I_{ZT} = 2.0 мА) = 28.0...32.0 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 2.0 мА) < 80 Ом; I_{ZM} = 250 мА$	SOT-89, SC-62	А•К•А•К
X5	BZV49C39	ZETEX	dz	$V_Z (I_{ZT} = 2.0 мА) = 37.0...41.0 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 2.0 мА) < 130 Ом; I_{ZM} = 250 мА$	SOT-89, SC-62	А•К•А•К
X6	BZV49C43	ZETEX	dz	$V_Z (I_{ZT} = 2.0 мА) = 40.0...46.0 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 2.0 мА) < 150 Ом; I_{ZM} = 250 мА$	SOT-89, SC-62	А•К•А•К
XC	RN5003	TOSH	Dnnpn	$V_{CE0} = 30 В; I_C = 2 А; P_D = 500 мВт; f_T = 120 МГц; R_1 = 10 кОм$	SOT-89, SC-62	В•С•Е•С
Y1	BZV49C11	ZETEX	dz	$V_Z (I_{ZT} = 5.0 мА) = 10.4...11.6 В; Z_{ZT} (I_{ZT} = 5.0 мА) < 20 Ом; I_{ZM} = 250 мА$	SOT-89, SC-62	А•К•А•К

**TO263
D2PAK**



**TO252
DPAK**



**SOT223
TO261A**



**SOT89
SC62**



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4
Y4	BZV49C15	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) = 13.8...15.6\text{ B}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 30\text{ Ом}$; $I_{2M} = 250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Y5	BZV49C16	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) = 15.3...17.1\text{ B}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 40\text{ Ом}$; $I_{2M} = 250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Y8	BZV49C22	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) = 20.8...23.3\text{ B}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 55\text{ Ом}$; $I_{2M} = 250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Y9	BZV49C24	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) = 22.8...25.6\text{ B}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 70\text{ Ом}$; $I_{2M} = 250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
YA	RN6001	TOSH	Dnprn	$V_{DS} = 30\text{ B}$; $I_C = 2\text{ A}$; $P_D = 500\text{ мВт}$; $f_T = 120\text{ МГц}$; $R_{\theta} = 2\text{ кОм}$	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
YB	2SK680A	NEC	nMOS	$V_{DS} = 30\text{ B}$; $I_D = 1\text{ A}$; $P_D = 2\text{ Вт}$; $R_{DS(on)} < 1\text{ Ом}$	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
YB	RN6002	TOSH	Dnprn	$V_{DS} = 30\text{ B}$; $I_C = 2\text{ A}$; $P_D = 500\text{ мВт}$; $f_T = 120\text{ МГц}$; $R_{\theta} = 5.6\text{ кОм}$	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
YK	2SB1115K	NEC	pnp	$V_{CE0} = 60\text{ B}$; $I_C = 1\text{ A}$; $P_D = 2\text{ Вт}$; $h_{21} = 300...600$; $f_T > 80\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
YL	2SB1115L	NEC	pnp	$V_{CE0} = 60\text{ B}$; $I_C = 1\text{ A}$; $P_D = 2\text{ Вт}$; $h_{21} = 200...400$; $f_T > 80\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
YM	2SB1115M	NEC	pnp	$V_{CE0} = 60\text{ B}$; $I_C = 1\text{ A}$; $P_D = 2\text{ Вт}$; $h_{21} = 135...270$; $f_T > 80\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
YP	2SB1115AP	NEC	pnp	$V_{CE0} = 80\text{ B}$; $I_C = 1\text{ A}$; $P_D = 2\text{ Вт}$; $h_{21} = 200...400$; $f_T > 80\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
YQ	2SB1115AQ	NEC	pnp	$V_{CE0} = 80\text{ B}$; $I_C = 1\text{ A}$; $P_D = 2\text{ Вт}$; $h_{21} = 135...270$; $f_T > 80\text{ МГц}$	SOT-89, SC-62	B•C•E•C
Z1	BZV49C10	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) = 9.4...10.6\text{ B}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 20\text{ Ом}$; $I_{2M} = 250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z1	BZV49C4V7	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) = 4.4...5.0\text{ B}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 80\text{ Ом}$; $I_{2M} = 250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z2	BZV49C5V1	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) = 4.8...5.4\text{ B}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 60\text{ Ом}$; $I_{2M} = 250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z3	2SK1078	TOSH	nMOS	$V_{DS} = 60\text{ B}$; $I_D = 800\text{ mA}$; $P_D = 500\text{ мВт}$; $R_{DS(on)} < 1.1\text{ Ом}$	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
Z3	BZV49C5V6	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) = 5.2...6.0\text{ B}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 40\text{ Ом}$; $I_{2M} = 250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z4	2SK1079	TOSH	nMOS	$V_{DS} = 100\text{ B}$; $I_D = 600\text{ mA}$; $P_D = 500\text{ мВт}$; $R_{DS(on)} < 1.8\text{ Ом}$	SOT-89, SC-62	S•D•G•D
Z4	BZV49C6V2	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) = 5.8...6.6\text{ B}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 10\text{ Ом}$; $I_{2M} = 250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z5	2SK1717	TOSH	nMOS	$V_{DS} = 60\text{ B}$; $I_D = 2\text{ A}$; $P_D = 500\text{ мВт}$; $R_{DS(on)} < 0.53\text{ Ом}$	SOT-89, SC-62	G•D•S•D
Z5	BZV49C6V8	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) = 6.4...7.2\text{ B}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 15\text{ Ом}$; $I_{2M} = 250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z6	2SJ238	TOSH	pMOS	$V_{DS} = 60\text{ B}$; $I_D = 1\text{ A}$; $P_D = 500\text{ мВт}$; $R_{DS(on)} = 1.4\text{ Ом}$	SOT-89, SC-62	G•D•S•D
Z6	BZV49C7V5	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) = 7.0...7.9\text{ B}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 15\text{ Ом}$; $I_{2M} = 250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z7	BZV49C8V2	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) = 7.7...8.7\text{ B}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 15\text{ Ом}$; $I_{2M} = 250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K
Z8	BZV49C9V1	ZETEX	dz	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) = 8.5...9.6\text{ B}$; $Z_{T1}(I_{ZT}=5.0\text{ mA}) < 15\text{ Ом}$; $I_{2M} = 250\text{ mA}$	SOT-89, SC-62	A•K•A•K



SOT143/R MW-4
SOT343/R

SC82

SC61



MFPK-4
TSFP-4

SOT143/343...

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
18	BFP181T	TELEF	npn	$V_{CB0} = 15 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 160 \text{ мВт}; h_{21} = 50...150;$ $f_T = 8 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
67	BFP67	TELEF	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 65...150;$ $f_T = 7.5 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
77	MA4CS101E	M/A	shd x2	$V_R = 70 \text{ В}; I_F < 15 \text{ мА}; V_F (I_F = 15 \text{ мА}) < 1 \text{ В}; C_D < 2 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	K2•K1•A1•A2
67	MA4CS102E	M/A	shd x2	$V_R = 8 \text{ В}; I_F < 30 \text{ мА}; V_F (I_F = 10 \text{ мА}) < 500 \text{ мВ}; C_D < 1 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	K2•K1•A1•A2
822	S822T	VISH	npn	$V_{CB0} = 12 \text{ В}; I_C = 8 \text{ мА}; P_D = 30 \text{ мВт}; h_{21} = 40...150;$ $f_T = 5.2 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
01	MRF9011LT1	MOT	npn	$V_{CB0} = 25 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 30...200;$ $f_T = 3800 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
02	MRF5711LT1	MOT	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 80 \text{ мА}; P_D = 580 \text{ мВт}; h_{21} = 50...300;$ $f_T = 8000 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
04	MRF4427	MOT	npn	$V_{CB0} = 40 \text{ В}; I_C = 400 \text{ мА}; P_D = 220 \text{ мВт}; h_{21} = 10...200;$ $f_T = 1600 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
04	MRF5211LT1	MOT	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 70 \text{ мА}; P_D = 333 \text{ мВт}; h_{21} = 25...125;$ $f_T = 4200 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
05	MRF9331LT1	MOT	npn	$V_{CB0} = 15 \text{ В}; I_C = 2 \text{ мА}; P_D = 50 \text{ мВт}; h_{21} = 30...200;$ $f_T = 5000 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
05F	TSDF1205R	TELEF	npn	$V_{CB0} = 9 \text{ В}; I_C = 12 \text{ мА}; P_D = 40 \text{ мВт}; h_{21} = 50...250;$ $f_T = 12 \text{ ГГц}$	SOT143R	C•E•B•E
11	MRF9511ALT1	MOT	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 322 \text{ мВт}; h_{21} = 75...150;$ $f_T = 8000 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
17	BAS125-07	SIEM	shd x2	$V_R < 25 \text{ В}; I_F < 100 \text{ мА}; V_F (I_F = 35 \text{ мА}) < 0.9 \text{ В}; I_S < 1.0 \text{ мкА};$ $C_D < 1.1 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
17s	BAS125-07	INF	shd x2	$V_R < 25 \text{ В}; I_F < 100 \text{ мА}; V_F (I_F = 35 \text{ мА}) < 0.9 \text{ В}; I_S < 1.0 \text{ мкА};$ $C_D < 1.1 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
17s	BAS125-07W	INF	shd x2	$V_R < 25 \text{ В}; I_F < 100 \text{ мА}; V_F (I_F = 35 \text{ мА}) < 0.9 \text{ В}; I_S < 1.0 \text{ мкА};$ $C_D < 1.1 \text{ нФ}$	SOT343, SC82A	K1•K2•A2•A1
18	MRF9331LT1	MOT	npn	$V_{CB0} = 15 \text{ В}; I_C = 2 \text{ мА}; P_D = 50 \text{ мВт}; h_{21} = 30...200;$ $f_T = 3500 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
18	MRF9411BLT1	MOT	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 100...200;$ $f_T = 8000 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
18	MRF9411BLT3	MOT	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 100...200;$ $f_T = 8000 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
1Jp	BCV61A	PHIL	npn x2	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 110...220;$ $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
1Jp	BCV61A	PHIL	npn x2	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 110...220;$ $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
1JS	BCV61A	INF	npn x2	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 110...220;$ $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
1Js	BCV61A	INF	npn x2	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 110...220;$ $f_T = 250 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	C1, B1, B2•C2•E2•E1
1Kp	BCV61B	PHIL	npn x2	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 200...450;$ $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
1Ks	BCV61B	INF	npn x2	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 200...450;$ $f_T = 250 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	C1, B1, B2•C2•E2•E1
1Lp	BCV61C	PHIL	npn x2	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 420...800;$ $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
1Ls	BCV61C	INF	npn x2	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} = 420...800;$ $f_T = 250 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	C1, B1, B2•C2•E2•E1
1Mp	BCV61	PHIL	npn x2	$V_{CB0} = 30 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 110...800;$ $f_T > 100 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	B1, B2, C2•C1•E1•E2
20	MRF5811LT1	MOT	npn	$V_{CB0} = 36 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 710 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T = 5 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•E•B

MFPAK-4
TSFP-4



SC61

SC82

MW-4

SOT143R
SOT343R



Код	Типономиннал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
20F	TSDF1220R	TELEF	npn	$V_{CB0} = 9\text{ В}; I_C = 40\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 50...150;$ $f_T = 12\text{ ГГц}$	SOT143R	С•Е•В•Е
28	BFP280T	TELEF	npn	$V_{CB0} = 15\text{ В}; I_C = 10\text{ мА}; P_D = 80\text{ мВт}; h_{21} = 50...150;$ $f_T = 7\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
305	AT30511	HP	npn	$V_{CB0} = 11\text{ В}; I_C = 8\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; h_{21} = 70...300;$ $f_T = 10\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	В•Е•С•Е
310	AT31011	HP	npn	$V_{CB0} = 11\text{ В}; I_C = 16\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 70...300;$ $f_T = 10\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	В•Е•С•Е
320	AT32011	HP	npn	$V_{CB0} = 11\text{ В}; I_C = 32\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 70...300;$ $f_T = 10\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	В•Е•С•Е
3Jp	BCV62A	PHIL	prnp x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 125...250;$ $f_T > 100\text{ МГц}$	SOT143, TO253	В1, В2, С2•С1•Е1•Е2
3Js	BCV62A	INF	prnp x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} = 125...220;$ $f_T = 250\text{ МГц}$	SOT143, TO253	С1, В1, В2•С2•Е2•Е1
3Kp	BCV62B	PHIL	prnp x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 220...475;$ $f_T > 100\text{ МГц}$	SOT143, TO253	В1, В2, С2•С1•Е1•Е2
3Ks	BCV62B	INF	prnp x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} = 220...475;$ $f_T = 250\text{ МГц}$	SOT143, TO253	С1, В1, В2•С2•Е2•Е1
3Lp	BCV62C	PHIL	prnp x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 420...800;$ $f_T > 100\text{ МГц}$	SOT143, TO253	В1, В2, С2•С1•Е1•Е2
3Ls	BCV62C	INF	prnp x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} = 420...800;$ $f_T = c250\text{ МГц}$	SOT143, TO253	С1, В1, В2•С2•Е2•Е1
3Mp	BCV62	PHIL	prnp x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 100...800;$ $f_T > 100\text{ МГц}$	SOT143, TO253	В1, В2, С2•С1•Е1•Е2
3Ms	BCV62	INF	prnp x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 100...800;$ $f_T > 100\text{ МГц}$	SOT143, TO253	В1, В2, С2•С1•Е1•Е2
3RP	3SK184P	PAN	dnMESFET	$V_{DS} = 13\text{ В}; I_D = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_e > 18\text{ мСм};$ $I_{DSS} = 8.5...17\text{ mA}$	SOT143, TO253	С•D•G2•G1
3RQ	3SK184Q	PAN	dnMESFET	$V_{DS} = 13\text{ В}; I_D = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_e > 18\text{ мСм};$ $I_{DSS} = 15...21\text{ mA}$	SOT143, TO253	С•D•G2•G1
3RR	3SK184R	PAN	dnMESFET	$V_{DS} = 13\text{ В}; I_D = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_e > 18\text{ мСм};$ $I_{DSS} = 19...30\text{ mA}$	SOT143, TO253	С•D•G2•G1
3RS	3SK184S	PAN	dnMESFET	$V_{DS} = 13\text{ В}; I_D = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_e > 18\text{ мСм};$ $I_{DSS} = 25...35\text{ mA}$	SOT143, TO253	С•D•G2•G1
414	AT41411	HP	npn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 225\text{ мВт}; h_{21} = 30...270;$ $f_T = 7000\text{ МГц}$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
47s	BAS4007	SIEM	shd x2	$V_E < 40\text{ В}; I_E < 120\text{ мА}; V_F (I_F = 40\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; I_R < 1.0\text{ мкА};$ $C_D < 5.0\text{ нФ}$	SOT143, TO253	К1•К2•А2•А1
47s	BAS40-07	INF	shd x2	$V_E < 40\text{ В}; I_E < 120\text{ мА}; V_F (I_F = 40\text{ мА}) < 1\text{ В}; I_R < 1.0\text{ мкА};$ $C_D < 5\text{ нФ}$	SOT143, TO253	К1•К2•А2•А1
47s	BAS40-07W	INF	shd x2	$V_E < 40\text{ В}; I_E < 120\text{ мА}; V_F (I_F = 40\text{ мА}) < 1\text{ В}; I_R < 1.0\text{ мкА};$ $C_D < 5\text{ нФ}$	SOT343, SC82A	К1•К2•А2•А1
57	BAT1707	SIEM	shd x2	$V_E < 4\text{ В}; I_E < 130\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 0.6\text{ В}; I_R < 0.25\text{ мкА};$ $C_D < 0.75\text{ нФ}$	SOT143, TO253	К1•К2•А2•А1
57s	BAT17-07	INF	shd x2	$V_E < 4\text{ В}; I_E < 130\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 0.6\text{ В}; I_R < 0.25\text{ мкА};$ $C_D < 1\text{ нФ}$	SOT143, TO253	К1•К2•А2•А1
60	BAR60	SIEM	pin x3	$V_E < 100\text{ В}; I_E < 140\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 1.25\text{ В};$ $I_R < 0.1\text{ мкА}; C_D < 0.2\text{ нФ}$	SOT143, TO253	К1, К2, А3•К3•А1•А2
61	BAR61	SIEM	pin x3	$V_E < 100\text{ В}; I_E < 140\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 1.25\text{ В};$ $I_R < 0.1\text{ мкА}; C_D < 0.2\text{ нФ}$	SOT143, TO253	К2, К3•А1•К1, А2•А3
62	BAT62	SIEM	shd x2	$V_E < 40\text{ В}; I_E < 20\text{ мА}; V_F (I_F = 2\text{ мА}) < 1\text{ В}; I_R < 10\text{ мкА};$ $C_D < 0.6\text{ нФ}$	SOT143, TO253	А1•К2•А2•К1
62s	BAT62	INF	shd x2	$V_E < 40\text{ В}; I_E < 20\text{ мА}; V_F (I_F = 2\text{ мА}) < 1\text{ В}; I_R < 10\text{ мкА};$ $C_D < 0.6\text{ нФ}$	SOT143, TO253	А1•К2•А2•К1
62s	BAT62-07W	INF	shd x2	$V_E < 40\text{ В}; I_E < 20\text{ мА}; V_F (I_F = 2\text{ мА}) < 1\text{ В}; I_R < 10\text{ мкА};$ $C_D < 0.6\text{ нФ}$	SOT343, SC82A	К1•К2•А2•А1
63	BAT63	SIEM	shd x2	$V_E < 3\text{ В}; I_E < 100\text{ мА}; V_F (I_F = 1\text{ мА}) < 0.3\text{ В}; I_R < 0.01\text{ мкА};$ $C_D < 0.85\text{ нФ}$	SOT143, TO253	А1•К2•А2•К1
67R	BFP67R	TELEF	npn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 65...150;$ $f_T = 7.5\text{ ГГц}$	SOT143R	С•Е•В•Е



SOT143/R MW-4
SOT343/R

SC82

SC61

MFP4K-4
TSFP-4



MFP4K-4
TSFP-4

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
67s	BAT64-07	INF	shd x2	$V_R < 40\text{ В}; I_E < 250\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 0.75\text{ В}; I_B < 2.0\text{ мкА}; C_0 < 6\text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
67s	BAT64-07W	INF	shd x2	$V_R < 40\text{ В}; I_E < 250\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 0.75\text{ В}; I_B < 2\text{ мкА}; C_0 < 6\text{ нФ}$	SOT343, SC82A	K1•K2•A2•A1
77p	BAS7007	PHIL	shd x2	$V_R < 70\text{ В}; I_E < 70\text{ мА}; V_F (I_F = 1\text{ мА}) < 410\text{ мВ}; C_0 < 2\text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
77s	BAS7007	SIEM	shd x2	$V_R < 70\text{ В}; I_E < 70\text{ мА}; V_F (I_F = 15\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; I_B < 0.1\text{ мкА}; C_0 < 2.0\text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
77s	BAS70-07	INF	shd x2	$V_R < 70\text{ В}; I_E < 70\text{ мА}; V_F (I_F = 15\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; I_B < 0.1\text{ мкА}; C_0 < 2.0\text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
77s	BAS70-07W	INF	shd x2	$V_R < 70\text{ В}; I_E < 70\text{ мА}; V_F (I_F = 15\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; I_B < 0.1\text{ мкА}; C_0 < 2.0\text{ нФ}$	SOT343, SC82A	K1•K2•A2•A1
82P	BFP182T	TELEF	npn	$V_{CE0} = 15\text{ В}; I_C = 35\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 50...150; f_T = 7.5\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
8372	MRF8372	MOT	npn	$V_{CE0} = 36\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; P_D = 1880\text{ мВт}; h_{21} = 30...200$	SOT143, TO253	C•E•B•E
83P	BFP183T	TELEF	npn	$V_{CE0} = 15\text{ В}; I_C = 65\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 50...150; f_T = 8\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
87s	BAT68-07	INF	shd x2	$V_R < 8\text{ В}; I_E < 130\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 0.5\text{ В}; I_B < 0.1\text{ мкА}; C_0 < 1.0\text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
87s	BAT68-07W	INF	shd x2	$V_R < 8\text{ В}; I_E < 130\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 0.5\text{ В}; I_B < 0.1\text{ мкА}; C_0 < 1.0\text{ нФ}$	SOT343, SC82A	K1•K2•A2•A1
8ALx	STM811L	STM	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 15\text{ мкА}$	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8AMx	STM811M	STM	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 15\text{ мкА}$	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8ANx	STM811T	STM	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 15\text{ мкА}$	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8APx	STM811S	STM	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 15\text{ мкА}$	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8AQx	STM811R	STM	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 15\text{ мкА}$	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8ARx	STM812L	STM	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 15\text{ мкА}$	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8ASx	STM812M	STM	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 15\text{ мкА}$	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8ATx	STM812T	STM	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 15\text{ мкА}$	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8AUX	STM812S	STM	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 15\text{ мкА}$	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
8AVx	STM812R	STM	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 15\text{ мкА}$	SOT143, TO253	VSS•RES•MR•VCC
92V	BFP92A	TELEF	npn	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 30\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 50...150; f_T = 6\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
97p	BCV65	PHIL	npn(1)+npn(2)	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 75...800$	SOT143, TO253	C2•B1, B2•C1•E1, E2
98p	BCV65B	PHIL	npn(1)+npn(2)	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 200...475$	SOT143, TO253	C2•B1, B2•C1•E1, E2
A	MRF947T3	MOT	npn	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 188\text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T = 8000\text{ МГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
A03	VAM-3	MC	amp	$V_{CC} = 4.7\text{ В}; I_{CC} = 35\text{ мА}; I_F = 0...2\text{ ГГц}; \text{GAIN} = 9.5\text{ дБ}$	SOT143, TO253	VCC, RF-OUT•GND•RF-IN•GND
A06	VAM-6	MC	amp	$V_{CC} = 3.3\text{ В}; I_{CC} = 16\text{ мА}; I_F = 0...2\text{ ГГц}; \text{GAIN} = 10\text{ дБ}$	SOT143, TO253	VCC, RF-OUT•GND•RF-IN•GND
A07	VAM-7	MC	amp	$V_{CC} = 3.8\text{ В}; I_{CC} = 22\text{ мА}; I_F = 0...2\text{ ГГц}; \text{GAIN} = 9.8\text{ дБ}$	SOT143, TO253	VCC, RF-OUT•GND•RF-IN•GND
A1	1SS272	TOSH	di x2	$V_R > 80\text{ В}; I_E < 300\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 1.2\text{ В}; I_B < 0.5\text{ мкА}; I_{RR} < 4\text{ нс}$	SC61, MPAK-4	K1•K2•A2•A1
A1	1SS382	TOSH	di x2	$V_R < 80\text{ В}; I_E < 300\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 1.2\text{ В}; I_B < 0.5\text{ мкА}; I_{RR} < 4\text{ нс}$	SC82, USQ	A1•A2•K2•K1
A2	CFY30	SIEM	nFET	$\text{GaAs}; V_{DS} = 5\text{ В}; I_D = 80\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; I_{DSS} = 15...60\text{ мА}; g_F = 30\text{ мСм}$	SOT143, TO253	S•D•S•G
A3	1SS306	TOSH	di x2	$V_R < 200\text{ В}; I_E < 300\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 1.2\text{ В}; I_{RR} < 60\text{ нс}$	SC61, MPAK-4	K1•K2•A2•A1
A4	1SS319	TOSH	di x2	$V_R < 40\text{ В}; I_E < 300\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 0.6\text{ В}; I_B (V_R = 40\text{ В}) < 5\text{ мкА}$	SC61, MPAK-4	K1•K2•A2•A1
A4	1SS383	TOSH	shd x2	$V_R < 40\text{ В}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 0.6\text{ В}; I_B (V_R = 40\text{ В}) < 5\text{ мкА}; C_T < 25\text{ нФ}$	SC82, USQ	A1•A2•K2•K1
A5	1SS384	TOSH	shd x2	$V_R < 15\text{ В}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 0.5\text{ В}; I_B (V_R = 10\text{ В}) < 20\text{ мкА}; C_T < 40\text{ нФ}$	SC82, USQ	A1•A2•K2•K1

MFPAK-4
TSFP-4



SC61
1 1 4
2 2 4 3

SC82
1 1 4
2 2 4 3

MW-4
1 1 4
2 2 4 3

SOT143R
SOT343R



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
A5	1SS391	TOSH	shd x2	$V_B < 10\text{ В}; V_F(I_F = 100\text{ мА}) < 0.5\text{ В}; I_{R1}(V_R = 10\text{ В}) < 20\text{ мкА}; C_T < 20\text{ нФ}$	SC61, MPAK-4	K1•K2•A2•A1
A5	HSMS2805	HP	shd x2	$V_{BR} > 70\text{ В}; V_F(I_F = 15\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; I_{R1}(V_R = 50\text{ В}) < 200\text{ мА}; C_D < 2.0\text{ нФ}; R_D = 35\text{ Ом}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
A51	BRY62	PHIL	npn/npn	$V_{CB0} = 70\text{ В}; I_C = 175\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21\text{NPN}} > 50; h_{21\text{PNP}} > 3$	SOT143, TO253	AG•A•C•CG
A6	1SS399	TOSH	di x2	$V_B < 400\text{ В}; I_F < 100\text{ мА}; V_F(I_F = 100\text{ мА}) < 1.3\text{ В}; I_{R1} < 1.0\text{ мкА}$	SC61, MPAK-4	K1•K2•A2•A1
A61	BAS28	CSI	fid x2	$I_F < 250\text{ мА}; V_{BR} > 75\text{ В}; V_F(I_F = 10\text{ мА}) < 0.855\text{ В}; I_{R1} < 1000\text{ мА}; I_{RR} < 6.0\text{ нС}; C_D < 2.0\text{ нФ}$	SOT143, TO253	A1•A2•K2•K1
A7	1SS402	TOSH	shd x2	$V_F > 20\text{ В}; V_F(I_F = 50\text{ мА}) < 0.55\text{ В}; I_{R1}(V_R = 20\text{ В}) < 0.5\text{ мкА}; C_T < 5\text{ нФ}$	SC82, USQ	A1•A2•K2•K1
A7	HSMS2807	HP	shd x4	$V_{BR} > 70\text{ В}; V_F(I_F = 15\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; I_{R1}(V_R = 50\text{ В}) < 200\text{ мА}; C_D < 2.0\text{ нФ}; R_D = 35\text{ Ом}$	SOT143, TO253	K1, A4•K4, A3•K3, A2•K2, A1
A8	HSMS2808	HP	shd x4	$V_{BR} > 70\text{ В}; V_F(I_F = 15\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; I_{R1}(V_R = 50\text{ В}) < 200\text{ мА}; C_D < 2.0\text{ нФ}; R_D = 35\text{ Ом}$	SOT143, TO253	K1, K4•A4, K3•A3, A2•K2, A1
AAB	MAX6711LXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAC	MAX6711MXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAD	MAX6711TXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAE	MAX6711SXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAF	MAX6711RXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAG	MAX6711ZXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAH	MAX6712LXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAI	MAX6712MXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAJ	MAX6712TXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAK	MAX6712SXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAL	MAX6712RXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAM	MAX6712ZXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAN	MAX6713LXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAO	MAX6713MXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAP	MAX6713TXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAQ	MAX6713SXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAR	MAX6713RXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAS	MAX6713ZXS	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 60\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAT	MAX6384XS16D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.58\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 13\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAU	MAX6385XS26D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 13\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAV	MAX6386XS17D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.67\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 13\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
AAW	MAX6387XS31D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 13\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•RES IN•VCC
AAX	MAX6388XS29D1	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 13\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•RES IN•VCC
AAY	MAX6389XS22D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.2\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 13\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•RES IN•VCC
AAZ	MAX6390XS26D4	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 13\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
ABA	MAX6384XS46D2	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 13\text{ мкА}$	SOT343, SC82A	GND•RES•MR•VCC
ACs	BFP620F	SIEM	npn	$V_{CB0} = 7.5\text{ В}; I_C = 80\text{ мА}; P_D = 185\text{ мВт}; h_{21} = 110...270; f_T = 65\text{ ГГц}$	TSFP-4	B•E•C•E
AE	1SS383T1G	ON	shd x2	$V_B < 40\text{ В}; V_F(I_F = 100\text{ мА}) < 0.6\text{ В}; I_{R1}(V_R = 40\text{ В}) < 5\text{ мкА}; C_T < 25\text{ нФ}$	SC82, USQ	A1•A2•K2•K1
ALs	BFP405	SIEM	npn	$V_{CB0} = 15\text{ В}; I_C = 12\text{ мА}; P_D = 55\text{ мВт}; h_{21} = 50...150; f_T > 20\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	B•E•C•E
AMs	BFP420	SIEM	npn	$V_{CB0} = 15\text{ В}; I_C = 35\text{ мА}; P_D = 160\text{ мВт}; h_{21} = 50...150; f_T > 20\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	B•E•C•E
ANs	BFP450	SIEM	npn	$V_{CB0} = 15\text{ В}; I_C = 10\text{ мА}; P_D = 450\text{ мВт}; h_{21} = 50...150; f_T > 15\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	B•E•C•E



SOT143/R MW-4
SOT343/R

SC82

SC61



MFPAK-4
TSFP-4

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3*4
APs	BFP520	INF	npn	$V_{CB0} = 10\text{ В}; I_C = 40\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; h_{21} = 70...200;$ $f_T = 45\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	B•E•C•E
ATs	BFP540	SIEM	npn	$V_{CB0} = 14\text{ В}; I_C = 80\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T = 30\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	B•E•C•E
B08	SST6908	SIL	nFET	$V_{DS} = 30\text{ В}; P_D = 350\text{ мВт}; I_{DSS} > 2\text{ мА}; g_F = 3\text{ мСм}$	SOT143, TO253	G•PRDI•S•D
B09	SST6909	SIL	nFET	$V_{DS} = 30\text{ В}; P_D = 350\text{ мВт}; I_{DSS} > 10\text{ мА}; g_F = 0.4\text{ мСм}$	SOT143, TO253	G•PRDI•S•D
B10	SST6910	SIL	nFET	$V_{DS} = 30\text{ В}; P_D = 350\text{ мВт}; I_{DSS} > 10\text{ мА}; g_F > 1.2\text{ мСм}$	SOT143, TO253	G•PRDI•S•D
B5	HSMS2815	HP	shd x2	$V_{BR} > 20\text{ В}; V_F (I_F = 95\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; I_H (V_H = 15\text{ В}) < 200\text{ нА};$ $C_T < 1.2\text{ нФ}; P_D = 15\text{ Ом}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
B7	HSMS2817	HP	shd x4	$V_{BR} > 20\text{ В}; V_F (I_F = 35\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; I_H (V_H = 15\text{ В}) < 200\text{ нА};$ $C_D < 1.2\text{ нФ}; P_D = 15\text{ Ом}$	SOT143, TO253	K1, A4•K4, A3•K3, A2•K2, A1
B8	HSMS2818	HP	shd x4	$V_{BR} > 20\text{ В}; V_F (I_F = 35\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; I_H (V_H = 15\text{ В}) < 200\text{ нА};$ $C_D < 1.2\text{ нФ}; P_D = 15\text{ Ом}$	SOT143, TO253	K1, K4•A4, K3•A3, A2•K2, A1
BB	1SV237	TOSH	pin x2	$V_R > 50\text{ В}; I_F < 50\text{ мА}; V_F (I_F = 50\text{ мА}) = 0.95\text{ В}; I_H < 0.1\text{ мкА}$	SC61, MPAK-4	K1•K2•A2•A1
BB	1SV312	TOSH	pin x2	$V_R > 50\text{ В}; I_F < 50\text{ мА}; V_F (I_F = 50\text{ мА}) < 1\text{ В}; I_H < 0.1\text{ мкА}$	SC82, USQ	A1•A2•K2•K1
BBs	BAR81	INF	di	$V_R < 30\text{ В}; I_C < 100\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 1\text{ В};$ $I_S < 0.02\text{ мА}; C_D < 0.6\text{ нФ}$	SOT143, TO253	K•A•K•A
BBs	BAR81W	INF	di	$V_R < 30\text{ В}; I_C < 100\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 1\text{ В};$ $I_S < 0.02\text{ мА}; C_D < 0.6\text{ нФ}$	SOT343, SC82A	K•A•K•A
BLs	BGA310	INF	amp	$I_{CC} = 60\text{ мА}; G_{MM} = 9\text{ дБ} (f_T = 1\text{ ГГц})$	SOT143, TO253	OUT/BIAS•GND•IN•GND
BLs	BGA420	SIEM	amp	$I_{CC} = 15\text{ мА}; G_{MM} = 13\text{ дБ} (f_T = 1.8\text{ ГГц})$	SOT343, SC82A	IN•GND•OUT•VD
BMs	BGA312	INF	amp	$I_{CC} = 60\text{ мА}; G_{MM} = 11\text{ дБ} (f_T = 1\text{ ГГц})$	SOT143, TO253	OUT/BIAS•GND•IN•GND
BMs	BGA427	INF	amp	$V_{CC} = 2...5\text{ В}; I_{CC} = 25\text{ мА}; G_{MM} = 18.5\text{ дБ} (f_T = 1.8\text{ ГГц})$	SOT343, SC82A	IN•GND•VD•OUT
BNs	BGA318	INF	amp	$I_{CC} = 60\text{ мА}; G_{MM} = 16\text{ дБ} (f_T = 1\text{ ГГц})$	SOT143, TO253	OUT/BIAS•GND•IN•GND
BNs	BGA612	INF	amp	$V_{CC} = 2.4...3\text{ В}; I_{CC} = 80\text{ мА}; G_{MM} = 17\text{ дБ} (f_T = 1\text{ ГГц})$	SOT343, SC82A	IN•GND•OUT•GND
BOs	BGA614	INF	amp	$V_{CC} = 2.4...3\text{ В}; I_{CC} = 80\text{ мА}; G_{MM} = 17\text{ дБ} (f_T = 1\text{ ГГц})$	SOT343, SC82A	IN•GND•OUT•GND
BPp	BGA616	INF	amp	$V_{CC} = 4.5...6\text{ В}; I_{CC} = 80\text{ мА}; G_{MM} = 17\text{ дБ} (f_T = 1\text{ ГГц})$	SOT343, SC82A	IN•GND•OUT•GND
BRs	BGA622	INF	amp	$V_{CC} = 2.4...3\text{ В}; f_{BD} = 0.5...6\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	IN•GND•OUT•VCC
C5	HSMS2825	HP	shd x2	$V_{BR} > 15\text{ В}; V_F (I_F = 30\text{ мА}) < 0.7\text{ В}; I_H (V_H = 1\text{ В}) < 100\text{ нА};$ $C_D < 1.0\text{ нФ}; P_D = 12\text{ Ом}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
C7	HSMS2827	HP	shd x4	$V_{BR} > 15\text{ В}; V_F (I_F = 30\text{ мА}) < 0.7\text{ В}; I_H (V_H = 1\text{ В}) < 100\text{ нА};$ $C_T < 1.0\text{ нФ}; P_D = 12\text{ Ом}$	SOT143, TO253	K1, A4•K4, A3•K3, A2•K2, A1
C8	HSMS2828	HP	shd x4	$V_{BR} > 15\text{ В}; V_F (I_F = 30\text{ мА}) < 0.7\text{ В}; I_H (V_H = 1\text{ В}) < 100\text{ нА};$ $C_T < 1.0\text{ нФ}; P_D = 12\text{ Ом}$	SOT143, TO253	K1, K4•A4, K3•A3, A2•K2, A1
C9	HSMS2829	HP	shd x4	$V_{BR} > 15\text{ В}; V_F (I_F = 30\text{ мА}) < 0.7\text{ В}; I_H (V_H = 1\text{ В}) < 100\text{ нА};$ $C_T < 1.0\text{ нФ}; P_D = 12\text{ Ом}$	SOT143, TO253	K1, A2•A3, K4•A4, K2•K3, A1
C95	BCV64	PHIL	npn x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 110...800;$ $f_T > 100\text{ МГц}$	SOT143, TO253	B1, C2•C1•E1, E2•B2
C96	BCV64B	PHIL	npn x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 220...475;$ $f_T > 100\text{ МГц}$	SOT143, TO253	B1, C2•C1•E1, E2•B2
D1	SST211	TEMI C	nFET	$V_{DS} = 30\text{ В}; P_D = 300\text{ мВт}; I_{DSS} = 4...20\text{ мА}; R_{DS(on)} < 50\text{ Ом}$	SOT143, TO253	SUBSTR•S•D•G
D3	SST213	TEMI C	nFET	$V_{DS} = 10\text{ В}; P_D = 300\text{ мВт}; I_{DSS} = 4...20\text{ мА}; R_{DS(on)} < 50\text{ Ом}$	SOT143, TO253	SUBSTR•S•D•G
D5	SST215	TEMI C	nFET	$V_{DS} = 20\text{ В}; P_D = 300\text{ мВт}; I_{DSS} = 4...20\text{ мА}; R_{DS(on)} < 50\text{ Ом}$	SOT143, TO253	SUBSTR•S•D•G
D89	BAI74	STM	shd x2	$V_R < 30\text{ В}; I_F < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 1\text{ мА}) < 320\text{ мВ}; C_D < 10\text{ нФ};$ $t_{BR} < 5\text{ нс}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
D95	BCV63	PHIL	npn x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 110...800;$ $f_T > 100\text{ МГц}$	SOT143, TO253	B1, C2•C1•E1, E2•B2
D96	BCV63B	PHIL	npn x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} = 200...450;$ $f_T > 100\text{ МГц}$	SOT143, TO253	B1, C2•C1•E1, E2•B2
DF	MAX2611EUS	MAX	amp	$V_{CC} = 5\text{ В}; f_p = 0...1100\text{ МГц}; I_{CC} < 40\text{ мА}$	SOT143, TO253	OUT•GND•IN•GND
DG	MAX2630EUS	MAX	amp	$V_{CC} = 2.7...5.5\text{ В}; f_p < 900\text{ МГц}; I_{CC} = 6.6\text{ мА}$	SOT143, TO253	OUT•GND•IN•VCC
DHAA	MAX2650EUS	MAX	amp	$V_{CC} = 4.5...5.5\text{ В}; f_p < 900\text{ МГц}; I_{CC} = 22\text{ мА}$	SOT143, TO253	OUT•GND•IN•VCC

MFPAK-4
TSFP-4



SC61



SC82



MW-4



SOT143R



SOT343R



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3*4
DI	2SC3867	REN	nnpn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 20...200;$ $f_T > 1400\text{ МГц}$	SOT343, SC82A	B•E•C•n.c.
EC	2SC2732	REN	nnpn	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 20\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 30;$ $f_T > 700\text{ МГц}$	SOT343, SC82A	E•B•C•n.c.
EI	3SK182	REN	nMOS	$V_{DS} = 20\text{ В}; I_D = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G > 10\text{ дБ};$ $NF < 6.0\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
F05	TSDF1205	TELEF	nnpn	$V_{CB0} = 9\text{ В}; I_C = 12\text{ мА}; P_D = 40\text{ мВт}; h_{21} = 50...250; f_T = 12\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
F20	TSDF1220	TELEF	nnpn	$V_{CB0} = 9\text{ В}; I_C = 40\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 50...150;$ $f_T = 12\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
FAs	BFP81	SIEM	nnpn	$V_{CB0} = 25\text{ В}; I_C = 30\text{ мА}; P_D = 280\text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T > 5800\text{ МГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
FB	BFP17	INF	nnpn	$V_{CB0} = 12\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 280\text{ мВт}$	SOT143, TO253	E•C•E•B
FC	BFP29	SIEM	nnpn	$V_{CB0} = 15\text{ В}; I_C = 30\text{ мА}; P_D = 280\text{ мВт}$	SOT143, TO253	E•C•E•B
FES	BFP93A	SIEM	nnpn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T > 6000\text{ МГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
FI	3SK186	REN	nMOS	$V_{DS} = 12\text{ В}; I_D = 35\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G > 16\text{ дБ};$ $NF < 4.5\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
G2	CGY50	SIEM	amp	GaAs; $V_{CC} = 2.7...6\text{ В}; f_{3dB} = 0.1...3\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	GND/S•OUT/D• GND/S•IN/G
G5	HSPM3895	HP	pin x2	$I_C < 1\text{ А}; P_C < 250\text{ мВт}; V_{BR} > 100\text{ В}; P_G < 2.50\text{ мВ};$ $CT < 0.30\text{ нФ}$	SOT143, TO253	A1•A2•K2•K1
GC	2SC2734	REN	nnpn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 20...200;$ $f_T > 1.4\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	E•B•C•n.c.
GIA	2SC3957A	REN	dnnpn	$V_{CB0} = 40\text{ В}; I_C = 300\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт};$ $h_{21} = 2000...100000$	SOT143, TO253	C•n.c. • B•E
GIB	2SC3957B	REN	dnnpn	$V_{CB0} = 40\text{ В}; I_C = 300\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт};$ $h_{21} = 5000...100000$	SOT143, TO253	C•n.c. • B•E
HC	2SC2733	REN	nnpn	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 60; f_T > 600\text{ МГц}$	SOT343, SC82A	E•B•C•n.c.
HG	CFY77-08	SIEM	nFET	AlGaAs/InGaAs HEMT; $V_{DS} = 3.5\text{ В}; I_D = 60\text{ мА};$ $P_D = 180\text{ мВт}; NF = 0.8\text{ дБ}$	MW-4	S•D•S•G
HH	CFY77-10	SIEM	nFET	AlGaAs/InGaAs HEMT; $V_{DS} = 3.5\text{ В}; I_D = 60\text{ мА};$ $P_D = 180\text{ мВт}; NF = 1\text{ дБ}$	MW-4	S•D•S•G
HHs	BBY51-07	INF	var x2	$V_G < 7\text{ В}; I_C < 20\text{ мА}; I_S < 0.01\text{ мкА}; C_{1B} = 4.8...6.0\text{ нФ};$ $C_{2B}/C_{4V} = 1.55...2.15$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
HI	3SK188	REN	nMOS	$V_{DS} = 22\text{ В}; I_D = 35\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G > 18\text{ дБ};$ $NF < 3.2\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
ID	2SC3127	REN	nnpn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G = 10.5\text{ дБ};$ $f_T > 3500\text{ МГц}$	SOT343, SC82A	E•B•C•n.c.
IJ	2SC3374	REN	nnpn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 20\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 20...200;$ $f_T > 400\text{ МГц}$	SOT343, SC82A	E•B•C•n.c.
IL	2SC3493	REN	nnpn	$V_{CB0} = 15\text{ В}; I_C = 20\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 30...200;$ $f_T > 700\text{ МГц}$	SOT343, SC82A	E•B•C•n.c.
IP	2SC3793	REN	nnpn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T > 1400\text{ МГц}$	SOT343, SC82A	E•B•C•n.c.
IS	2SC3513	REN	nnpn	$V_{CB0} = 15\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 50...250;$ $f_T > 4500\text{ МГц}$	SOT343, SC82A	E•B•C•n.c.
IT	3SK162	REN	dnMOS	$V_{DS} = 12\text{ В}; I_D = 35\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G > 18\text{ дБ};$ $NF < 3.0\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
IV	2SK668	REN	nFET	GaAs; $V_{DS} = 6.0\text{ В}; I_D = 100\text{ мА}; P_{CH} = 150\text{ мВт}; P_G = 10\text{ дБ};$ $NF = 2.5\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	G•S•D•G
IV	3SK136	REN	dnMOS	$V_{DS} = 20\text{ В}; I_D = 35\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G > 17\text{ дБ};$ $NF < 3.3\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
IW	3SK137	REN	dnMOS	$V_{DS} = 15\text{ В}; I_D = 35\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G > 10\text{ дБ};$ $NF < 5.0\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
IW	3SK137V	REN	dnMOS	$V_{DS} = 15\text{ В}; I_D = 35\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G > 20\text{ дБ};$ $NF < 3.0\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
IX	3SK138	REN	dnMOS	$V_{DS} = 15\text{ В}; I_D = 35\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G > 10\text{ дБ};$ $NF < 5.0\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1



SOT143/R MW-4
SOT343/R 2 4 3



MFPK-4
TSFP-4

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
IY	3SK194	REN	nMOS	$V_{DS} = 15\text{ В}; I_D = 35\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G > 27\text{ дБ};$ $NF < 2.5\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
IZ	3SK154	REN	dmMOS	$V_{DS} = 15\text{ В}; I_D = 35\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G > 22\text{ дБ};$ $NF < 3.0\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
JC	2SC2735	REN	nnpn	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 40;$ $f_T > 600\text{ МГц}$	SOT343, SC82A	E•B•C•n. c.
JKs	BF1009	INF	dmMOS	$V_{DS} = 12\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f = 24\text{ мСм}$	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
JLs	BF1009S	INF	dmMOS	$V_{DS} = 12\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f = 30\text{ мСм}$	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
JLs	BF1009SR	INF	dmMOS	$V_{DS} = 12\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f = 30\text{ мСм}$	SOT143R	D•S•G1•G2
JPs	BAW101	SIEM	di x2	$V_R < 300\text{ В}; I_R < 250\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 1.3\text{ В};$ $I_R < 0.15\text{ мкА}; C_0 < 6.0\text{ нФ}; t_{RR} < 1000\text{ нс}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
JSs	BAW100	SIEM	di x2	$V_R < 75\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 150\text{ мА}) < 1.25\text{ В};$ $I_R < 1.0\text{ мкА}; C_0 < 2.0\text{ нФ}; t_{RR} < 6\text{ нс}$	SOT143, TO253	A1•A2•K2•K1
JTp	BAS28	PHIL	fd x2	$V_R < 75\text{ В}; I_R < 215\text{ мА}; V_F (I_F = 50\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; C_0 < 1.5\text{ нФ};$ $t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
JTs	BAS28	INF	di x2	$V_R < 75\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 50\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; I_R < 0.1\text{ мкА};$ $C_0 < 2.0\text{ нФ}; t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
JTs	BAS28W	INF	di x2	$V_R < 75\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 50\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; I_R < 0.1\text{ мкА};$ $C_0 < 2.0\text{ нФ}; t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOT343, SC82A	K1•K2•A2•A1
JXAA	MAX6160EUS	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6\text{ В}; I_{CC} < 130\text{ мкА}; V_{OUT} = 1.23...12.4\text{ В}$	SOT143, TO253	GND•ADJ•IN•OUT
KAAP	MAX6335US16D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.6\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KAAQ	MAX6335US18D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.8\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KAAR	MAX6335US22D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.2\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KAAS	MAX6336US16D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.6\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KAAT	MAX6336US18D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.8\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KAAU	MAX6336US20D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.0\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KAAV	MAX6336US22D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.2\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KAAW	MAX6336US23D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.3\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KAAX	MAX6337US16D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.6\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KAAY	MAX6337US18D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.8\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KAZ	MAX6337US22D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.2\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KABA	MAX6816EUS	MAX	swd	$V_{CC} = 2.7...5.5\text{ В}; I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•IN•OUT•VCC
KABP	MAX6335US20D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.0\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KABQ	MAX6335US23D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.3\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KABR	MAX6337US20D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.0\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KABS	MAX6337US23D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.3\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KABT	MAX6806US46	MAX	vd	$V_{TR} = 4.6\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 80\text{ мкА}$	SOT143, TO253	RES•MR•VCC•GND
KABU	MAX6806US26	MAX	vd	$V_{TR} = 2.6\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 80\text{ мкА}$	SOT143, TO253	RES•MR•VCC•GND
KABV	MAX6806US23	MAX	vd	$V_{TR} = 2.3\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 80\text{ мкА}$	SOT143, TO253	RES•MR•VCC•GND
KABW	MAX6807US46	MAX	vd	$V_{TR} = 4.6\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 80\text{ мкА}$	SOT143, TO253	RES•MR•VCC•GND
KABX	MAX6807US26	MAX	vd	$V_{TR} = 2.6\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 80\text{ мкА}$	SOT143, TO253	RES•MR•VCC•GND
KABY	MAX6808US46	MAX	vd	$V_{TR} = 4.6\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 80\text{ мкА}$	SOT143, TO253	RES•MR•VCC•GND
KABZ	MAX6808US26	MAX	vd	$V_{TR} = 2.6\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 80\text{ мкА}$	SOT143, TO253	RES•MR•VCC•GND
KACA	MAX6336US25D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KACB	MAX6337US17D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.7\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KACC	MAX6808US32	MAX	vd	$V_{TR} = 3.2\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 80\text{ мкА}$	SOT143, TO253	RES•MR•VCC•GND
KACE	MAX6337US16D2	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.6\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KACF	MAX6336US24D1	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.4\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 7\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KACH	MAX6803US26D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 12\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KACI	MAX6803US29D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 12\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KACJ	MAX6803US31D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 12\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KACK	MAX6803US44D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 12\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KACL	MAX6803US46D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 12\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
KACN	MAX6804US26D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 12\text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC

MFPK-4
TSFP-4



SC61

SC82

MW-4

SOT143R
SOT343R



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
KACO	MAX6804US29D2	MAX	micr	$V_{TR} = 2.93 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 12 \text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACP	MAX6804US29D3	MAX	micr	$V_{TR} = 2.93 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 12 \text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACO	MAX6804US31D3	MAX	micr	$V_{TR} = 3.08 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 12 \text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACR	MAX6804US44D3	MAX	micr	$V_{TR} = 4.38 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 12 \text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACS	MAX6804US46D3	MAX	micr	$V_{TR} = 4.63 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 12 \text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACT	MAX6805US26D3	MAX	micr	$V_{TR} = 2.63 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 12 \text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACU	MAX6805US29D3	MAX	micr	$V_{TR} = 2.93 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 12 \text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACV	MAX6805US31D3	MAX	micr	$V_{TR} = 3.08 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 12 \text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACW	MAX6805US44D3	MAX	micr	$V_{TR} = 4.38 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 12 \text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
KACX	MAX6805US46D3	MAX	micr	$V_{TR} = 4.63 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 12 \text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND • RES • MR • VCC
L30	BAV23	PHIL	dx2	$V_F < 200 \text{ В}; I_F < 225 \text{ мА}; V_F (I_F = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; C_0 < 5 \text{ нФ}; t_{RR} < 50 \text{ нс}$	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
L41	BAT74	PHIL	shd x2	$V_A < 30 \text{ В}; I_F < 200 \text{ мА}; V_F (I_F = 1 \text{ мА}) < 320 \text{ мВ}; C_0 < 10 \text{ нФ}; t_{RR} < 5 \text{ нс}$	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
L51	BAS56	PHIL	fd x2	$V_A < 60 \text{ В}; I_F < 200 \text{ мА}; V_F (I_F = 200 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; C_0 < 2.5 \text{ нФ}; t_{RR} < 6 \text{ нс}$	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
L51	BAS56	CNTR L	fd x2	$V_A < 60 \text{ В}; I_F < 200 \text{ мА}; V_F (I_F = 200 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; C_0 < 2.5 \text{ нФ}; t_{RR} < 6 \text{ нс}$	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
L51	BAS56	CSI	fid x2	$V_{BR} > 60 \text{ В}; I_C < 200 \text{ мА}; V_F (I_F = 10 \text{ мА}) < 0.75 \text{ В}; I_F < 100 \text{ мА}; t_{RR} < 6.0 \text{ нс}; C_0 < 2.5 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	A1 • A2 • K2 • K1
M	BAF6507	SIEM	pin x2	$V_A < 30 \text{ В}; I_F < 100 \text{ мА}; V_F (I_F = 50 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; C_0 < 0.9 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1 • K2 • A2 • A1
M01	BF901	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 12 \text{ В}; I_{DS} = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 28 \text{ мС}$	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M02	BF901R	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 12 \text{ В}; I_{DS} = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 28 \text{ мС}$	SOT143R	S • D • G2 • G1
M04	BF904	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 7 \text{ В}; I_{DS} = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 25 \text{ мС}$	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M06	BF904R	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 7 \text{ В}; I_{DS} = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 25 \text{ мС}$	SOT143R	S • D • G2 • G1
M26	BF908	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 12 \text{ В}; I_{DS} = 40 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 43 \text{ мС}$	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M27	BF908R	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 12 \text{ В}; I_{DS} = 40 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 43 \text{ мС}$	SOT143R	S • D • G2 • G1
M28	BF909	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 7 \text{ В}; I_{DS} = 40 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 43 \text{ мС}$	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M29	BF909R	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 7 \text{ В}; I_{DS} = 40 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 43 \text{ мС}$	SOT143R	S • D • G2 • G1
M31	BSD20	PHIL	nMOS	$V_{DS} = 10 \text{ В}$	SOT343, SC82A	G • S • D
M32	BSD22	PHIL	nMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 50 \text{ мА}; P_D = 230 \text{ мВт}$	SOT143, TO253	SUB • S • D • G
M52	BF932R	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 40 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f > 25 \text{ мСМ}$	SOT143R	S • D • G2 • G1
M56	BF1100	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 14 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 28 \text{ мСМ}$	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M57	BF1100R	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 14 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 28 \text{ мСМ}$	SOT143R	S • D • G2 • G1
M74	BSS83	PHIL	nMOS	$V_{DS} = 10 \text{ В}; I_D = 50 \text{ мА}; P_D = 230 \text{ мВт}; P_{D(ON)} < 45 \text{ Ом}$	SOT143, TO253	SUB • S • D • G
M87	BF990A	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 18 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 2 \text{ дБ}; g_f > 18 \text{ мСМ}$	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M90	BF990	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 18 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 2 \text{ дБ}; g_f > 18 \text{ мСМ}$	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M91	BF991	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 20 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 2 \text{ дБ}; g_f > 14 \text{ мСМ}$	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M92	BF992	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 40 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f > 25 \text{ мСМ}$	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M94	BF994	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; I_{DS} = 4...18 \text{ мА}; g_f > 15 \text{ мСМ}$	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
M96	BF996	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 1.8 \text{ дБ}; I_{DSS} = 2...20 \text{ мА}; g_f > 15 \text{ мСМ}$	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MAp	BF989	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_{DS} = 20 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f > 12 \text{ мС}$	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MB	BF995	SIEM	dnMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 1.1 \text{ дБ}; I_{DSS} = 4...20 \text{ мА}; g_f > 12 \text{ мСМ}$	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MB	BF995	TELEF	dnMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; I_{DS} = 4...18 \text{ мА}; g_f > 12 \text{ мСМ}$	SOT143, TO253	S • D • G2 • G1
MB	BF998WR	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 12 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f > 24 \text{ мСМ}$	SOT343, SC82A	S • D • G2 • G1
MB3	ADM811-START	AD	micr	$V_{DS} = 3.08 \text{ В}; I_{RES} = 300...700 \text{ мС}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 15 \text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND • RES • RES • MR • VCC



SOT143/R MW-4
SOT343/R



SC82



MFPK-4
TSFP-4

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
MBB	ADM811RART	AD	mrc	$V_{TR} = 2,63$ В; $t_{RES} = 140 \dots 560$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES/RES•MR•VCC
MBE	ADM811SART	AD	mrc	$V_{TR} = 2,93$ В; $t_{RES} = 140 \dots 560$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES/RES•MR•VCC
MBG	ADM811TART	AD	mrc	$V_{TR} = 3,08$ В; $t_{RES} = 140 \dots 560$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES/RES•MR•VCC
MBT	ADM811MART	AD	mrc	$V_{TR} = 4,38$ В; $t_{RES} = 140 \dots 560$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES/RES•MR•VCC
MBV	ADM811LART	AD	mrc	$V_{TR} = 4,63$ В; $t_{RES} = 140 \dots 560$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES/RES•MR•VCC
MBZ	ADM811ZART	AD	mrc	$V_{TR} = 2,32$ В; $t_{RES} = 140 \dots 560$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES/RES•MR•VCC
MC	BF904WR	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 7$ В; $I_{OS} = 30$ мА; $P_D = 280$ мВт; $g_f = 25$ МГц	SOT343R	S•D•G2•G1
MCB	ADM812RART	AD	mrc	$V_{TR} = 2,63$ В; $t_{RES} = 140 \dots 560$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES/RES•MR•VCC
MCE	ADM812SART	AD	mrc	$V_{TR} = 2,93$ В; $t_{RES} = 140 \dots 560$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES/RES•MR•VCC
MCG	ADM812TART	AD	mrc	$V_{TR} = 3,08$ В; $t_{RES} = 140 \dots 560$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES/RES•MR•VCC
MCT	ADM812MART	AD	mrc	$V_{TR} = 4,38$ В; $t_{RES} = 140 \dots 560$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES/RES•MR•VCC
MCV	ADM812LART	AD	mrc	$V_{TR} = 4,63$ В; $t_{RES} = 140 \dots 560$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES/RES•MR•VCC
MCZ	ADM812ZART	AD	mrc	$V_{TR} = 2,32$ В; $t_{RES} = 140 \dots 560$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES/RES•MR•VCC
MD	BF908WR	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 12$ В; $I_{OS} = 40$ мА; $P_D = 300$ мВт; $g_f = 43$ МГц	SOT343R	S•D•G2•G1
MDB	ADM6315-26D1ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2,63$ В; $t_{RES} = 1$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MDC	ADM6315-29D1ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2,93$ В; $t_{RES} = 1$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MDG	ADM6315-31D1ART	AD	mrc	$V_{TR} = 3,08$ В; $t_{RES} = 1$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MDT	ADM6315-44D1ART	AD	mrc	$V_{TR} = 4,39$ В; $t_{RES} = 1$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MDU	ADM6315-45D1ART	AD	mrc	$V_{TR} = 4,5$ В; $t_{RES} = 1$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MDV	ADM6315-46D1ART	AD	mrc	$V_{TR} = 4,63$ В; $t_{RES} = 1$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MEB	ADM6315-26D2ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2,63$ В; $t_{RES} = 20$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MEC	ADM6315-29D2ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2,93$ В; $t_{RES} = 20$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MEG	ADM6315-31D2ART	AD	mrc	$V_{TR} = 3,08$ В; $t_{RES} = 20$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MET	ADM6315-44D2ART	AD	mrc	$V_{TR} = 4,39$ В; $t_{RES} = 20$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MEU	ADM6315-45D2ART	AD	mrc	$V_{TR} = 4,5$ В; $t_{RES} = 20$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MEV	ADM6315-46D2ART	AD	mrc	$V_{TR} = 4,63$ В; $t_{RES} = 20$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MF	BF1100WR	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 14$ В; $I_{OS} = 30$ мА; $P_D = 280$ мВт; $g_f = 28$ МГц	SOT343R	S•D•G2•G1
MFB	ADM6315-26D3ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2,63$ В; $t_{RES} = 140$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MFC	ADM6315-29D3ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2,93$ В; $t_{RES} = 140$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MFG	ADM6315-31D3ART	AD	mrc	$V_{TR} = 3,08$ В; $t_{RES} = 140$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MFT	ADM6315-44D3ART	AD	mrc	$V_{TR} = 4,39$ В; $t_{RES} = 140$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MFU	ADM6315-45D3ART	AD	mrc	$V_{TR} = 4,5$ В; $t_{RES} = 140$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MFV	ADM6315-46D3ART	AD	mrc	$V_{TR} = 4,63$ В; $t_{RES} = 140$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MG	BF994S	SIEM	dnMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_{OS} = 30$ мА; $P_D = 200$ мВт; $NF = 1$ дБ; $t_{DSS} = 2 \dots 20$ мА; $g_f > 15$ МГц	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
MG	BF994S	TELEF	dnMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_{OS} = 30$ мА; $P_D = 200$ мВт; $I_{OS} = 4 \dots 18$ мА; $g_f > 15$ МГц	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
MGB	ADM6315-26D4ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2,63$ В; $t_{RES} = 1120$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MGC	ADM6315-29D4ART	AD	mrc	$V_{TR} = 2,93$ В; $t_{RES} = 1120$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MGG	ADM6315-31D4ART	AD	mrc	$V_{TR} = 3,08$ В; $t_{RES} = 1120$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MGp	BF994S	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 20$ В; $I_{OS} = 30$ мА; $P_D = 200$ мВт; $I_{OS} = 4 \dots 18$ мА; $g_f > 15$ МГц	SOT143, TO253	S•D•G1•G2
MGT	ADM6315-44D4ART	AD	mrc	$V_{TR} = 4,39$ В; $t_{RES} = 1120$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MGU	ADM6315-45D4ART	AD	mrc	$V_{TR} = 4,5$ В; $t_{RES} = 1120$ мс; $V_{DD} = 1 \dots 5,5$ В; $I_{CC} < 15$ мкА	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC

MFPAK-4
TSFP-4



SC61

SC82

MW-4

SOT143R
SOT343R



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
MGV	ADM6315-46D4ART	AD	mrcs	$V_{TR} = 4.63 \text{ В}; I_{RES} = 1120 \text{ мкА}; V_{DD} = 1...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 15 \text{ мкА}$	SOT143, TO253	GND•RES•MR•VCC
MH	BF996S	SIEM	dnMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 1.8 \text{ дБ}; I_{BSS} = 2...20 \text{ мА}; g_e > 15 \text{ мСм}$	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
MH	BF996S	TELEF	dnMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; I_{BS} = 4...20 \text{ мА}; g_e > 15 \text{ мСм}$	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
MH	BF996S	VIS	dnMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 1.8 \text{ дБ}; g_e > 18 \text{ мСм}$	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
MHP	BF996S	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 1.8 \text{ дБ}; g_e > 18 \text{ мСм}$	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
MI	2SC4126	REN	npn	$V_{CBO} = 15 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 50...250; f_T > 4500 \text{ МГц}$	SOT343, SC82A	C•E•B•E
MK	BF997	SIEM	dnMOS	$V_{DS} = 20 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 1.0 \text{ дБ}; I_{BSS} = 2...20 \text{ мА}; g_e > 15 \text{ мСм}$	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
MO	BF998	VIS	dnMOS	$V_{DS} = 12 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; I_{BS} = 4...18 \text{ мА}; g_e > 21 \text{ мСм}$	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
MOp	BF998	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 12 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_e > 24 \text{ мСм}$	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
MOp	BF998R	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 12 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_e > 24 \text{ мСм}$	SOT143R	S•D•G2•G1
MOR	BF998R	VIS	dnMOS	$V_{DS} = 12 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; I_{BS} = 4...18 \text{ мА}; g_e > 21 \text{ мСм}$	SOT143R	S•D•G2•G1
MOs	BF998	INF	dnMOS	$V_{DS} = 12 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 1.0 \text{ дБ}; I_{BSS} = 2...20 \text{ мА}; g_e = 24 \text{ мСм}$	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
MR	BF998W	INF	dnMOS	$V_{DS} = 12 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 1.0 \text{ дБ}; I_{BSS} = 2...18 \text{ мА}; g_e = 24 \text{ мСм}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
MRs	BF998R	INF	dnMOS	$V_{DS} = 12 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 1.0 \text{ дБ}; I_{BSS} = 2...20 \text{ мА}; g_e = 24 \text{ мСм}$	SOT143R	S•D•G2•G1
Ms	BAR65-07	INF	pin x2	$V_f < 30 \text{ В}; I_C < 100 \text{ мА}; V_f (I_C = 100 \text{ мА}) < 1.0 \text{ В}; C_D < 0.9 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
MS	CF739	SIEM	nFET	$GaAs; V_{DS} = 10 \text{ В}; I_D = 80 \text{ мА}; P_D = 240 \text{ мВт}; I_{BSS} = 6...60 \text{ мА}; g_e = 25 \text{ мСм}$	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
MX	CF750	SIEM	nFET	$GaAs; V_{DS} = 8 \text{ В}; I_D = 80 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; I_{BSS} = 50 \text{ мА}; g_e = 25 \text{ мСм}$	SOT143, TO253	GND•D•G•S
MyS	BF1012	SIEM	dnMOS	$V_{DS} = 16 \text{ В}; I_D = 25 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 1.4 \text{ дБ}; g_e = 26 \text{ мСм}$	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
MyS	BF1012W	SIEM	dnMOS	$V_{DS} = 16 \text{ В}; I_D = 40 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 1.4 \text{ дБ}; g_e = 26 \text{ мСм}$	SOT343, SC82A	D•S•G1•G2
MZs	BF1005	SIEM	dnMOS	$V_{DS} = 8 \text{ В}; I_D = 25 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 1.4 \text{ дБ}; g_e = 24 \text{ мСм}$	SOT143, TO253	S•D•G2•G1
N20	DA227	ROHM	di x2	$V_f < 80 \text{ В}; I_C < 300 \text{ мА}; P_D < 200 \text{ мВт}; V_f (I_C = 100 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}; I_{RR} < 4 \text{ нС}$	SOT343, SC82A	K1•A1•A2•K2
N3	BFG520W	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 70 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 60; f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	C•B•E•E
N33	BFG505	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 18 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 60; f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•B•E•E
N36	BFG520	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 70 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 60; f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•B•E•E
N37	BFG540	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 120 \text{ мА}; P_D = 400 \text{ мВт}; h_{21} > 100; f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•B•E•E
N38	BFG590	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 400 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T = 5 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•B•E•E
N39	BFG505X	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 18 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} > 60; f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•B•E•E
N4	BFG520W/X	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 70 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 60; f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	C•E•B•E
N42	BFG520/X	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 70 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 60; f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
N43	BFG540/X	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 120 \text{ мА}; P_D = 400 \text{ мВт}; h_{21} > 100; f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
N44	BFG590X	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 200 \text{ мА}; P_D = 400 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T = 5 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
N48	BFG520/XR	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 70 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 60; f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT143R	C•E•B•E
N49	BFG540/XR	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 120 \text{ мА}; P_D = 400 \text{ мВт}; h_{21} > 100; f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT143R	C•E•B•E
N70	BFG10	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 250 \text{ мА}; P_D = 400 \text{ мВт}; h_{21} > 25; f_T > 1.8 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•B•E•E
N71	BFG10/X	PHIL	npn	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 250 \text{ мА}; P_D = 400 \text{ мВт}; h_{21} > 25; f_T > 1.8 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E



SOT143/R MW-4
SOT343/R



SC82
SC61



MPPAK-4
TSFP-4

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3*4
N72	BFG11	PHIL	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 400 \text{ мВт}; h_{21} > 25;$ $f_T > 1.8 \text{ ГГц}$	SOT143, T0253	C•B•E•E
N73	BFG11/X	PHIL	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 400 \text{ мВт}; h_{21} > 25;$ $f_T > 1.8 \text{ ГГц}$	SOT143, T0253	C•E•B•E
NA	BF1105WR	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 7 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 31 \text{ мСм}$	SOT343R	S•D•G2•G1
NA	CFY35-20	SIEM	nFET	GaAs; $V_{DS} = 5 \text{ В}; I_D = 60 \text{ мА}; P_D = 180 \text{ мВт}; NF = 2.0 \text{ дБ}$	MW-4	S•D•S•G
NAp	BF1105R	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 7 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 31 \text{ мСм}$	SOT143R	S•D•G2•G1
NB	BF1109WR	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 11 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 30 \text{ мСм}$	SOT343R	S•D•G2•G1
NB	CFY35-23	SIEM	nFET	GaAs; $V_{DS} = 5 \text{ В}; I_D = 60 \text{ мА}; P_D = 180 \text{ мВт}; NF = 2.3 \text{ дБ}$	MW-4	S•D•S•G
NBp	BF1109R	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 11 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 30 \text{ мСм}$	SOT143R	S•D•G2•G1
NEp	BF1105	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 7 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 31 \text{ мСм}$	SOT143, T0253	S•D•G2•G1
NFp	BF1109	PHIL	dnMOS	$V_{DS} = 11 \text{ В}; I_D = 30 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; g_f = 30 \text{ мСм}$	SOT143, T0253	S•D•G2•G1
Ni	3SK191	REN	nFET	GaAs; $V_{DS} = 12.0 \text{ В}; I_D = 80 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; P_G > 12 \text{ дБ};$ $NF < 3.0 \text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
NYs	BF1012S	SIEM	dnMOS	$V_{DS} = 16 \text{ В}; I_D = 25 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 1.4 \text{ дБ};$ $g_f = 26 \text{ мСм}$	SOT143, T0253	S•D•G2•G1
Nzs	BF1005S	SIEM	dnMOS	$V_{DS} = 8 \text{ В}; I_D = 25 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; NF = 1.6 \text{ дБ};$ $g_f = 24 \text{ мСм}$	SOT143, T0253	S•D•G2•G1
P5	HSM52855	HP	shd x2	$V_F (I_F = 1 \text{ мА}) < 0.25 \text{ В}; C_T = 0.3 \text{ нФ}$	SOT143, T0253	A1•A2•K2•K1
PAs	BFP136W	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 1000 \text{ мВт}; h_{21} = 80...250;$ $f_T > 5900 \text{ МГц}$	SOT343, SC82A	E•C•E•B
PTs	BAR6407	SIEM	pin x2	$V_R < 200 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}; V_F (I_F = 50 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В};$ $C_D < 0.35 \text{ нФ};$	SOT143, T0253	K1•K2•A2•A1
PTs	BAR64-07	INF	pin x2	$V_R < 150 \text{ В}; I_R < 100 \text{ мА}; V_F (I_F = 50 \text{ мА}) < 1.1 \text{ В};$ $C_D < 0.35 \text{ нФ}$	SOT143, T0253	K1•K2•A2•A1
QI	2SC4196	REN	npn	$V_{CB0} = 25 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 50...180;$ $f_T > 1800 \text{ МГц}$	SOT343, SC82A	E•B•C•n. c.
QV	1SV298	SANY O	pin x3	$V_R > 50 \text{ В}; I_R < 50 \text{ мА}; V_F (I_F = 50 \text{ мА}) = 0.92...0.97 \text{ В};$ $I_R < 0.1 \text{ мА}$	SOT143, T0253	K1, K2•A3•A2, K3•A1
R26	2SC4093Q	NEC	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 50...100;$ $f_T = 7 \text{ ГГц}$	SOT143, T0253	C•E•B•E
R26	2SC5011Q	NEC	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 50...100;$ $f_T = 6.5 \text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R27	2SC4093R	NEC	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 80...160;$ $f_T = 7 \text{ ГГц}$	SOT143, T0253	C•E•B•E
R27	2SC5011R	NEC	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 80...160;$ $f_T = 6.5 \text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R28	2SC4093S	NEC	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 125...250;$ $f_T = 7 \text{ ГГц}$	SOT143, T0253	C•E•B•E
R28	2SC5011S	NEC	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 125...250;$ $f_T = 6.5 \text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R2s	BFP620	SIEM	npn	$V_{CB0} = 7.5 \text{ В}; I_C = 80 \text{ мА}; P_D = 185 \text{ мВт}; h_{21} = 110...270;$ $f_T = 65 \text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	B•E•C•E
R36	2SC4094Q	NEC	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 65 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 50...100;$ $f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT143, T0253	C•E•B•E
R36	2SC5012Q	NEC	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 65 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 50...100;$ $f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R37	2SC4094R	NEC	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 65 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 80...160;$ $f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT143, T0253	C•E•B•E
R37	2SC5012R	NEC	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 65 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 80...160;$ $f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R38	2SC4094S	NEC	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 65 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 125...250;$ $f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT143, T0253	C•E•B•E
R38	2SC5012S	NEC	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 65 \text{ мА}; P_D = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 125...250;$ $f_T = 9 \text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R4	2SC4092	NEC	npn	$V_{CB0} = 25 \text{ В}; I_C = 70 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 40...120;$ $f_T = 6 \text{ ГГц}$	SOT143, T0253	C•E•B•E

MFPAK-4
TSFP-4



SC61

SC82

MW-4

SOT143R
SOT343R



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3*4
R46	2SC4095Q	NEC	npn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_c = 35\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 50...100;$ $f_T = 10\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
R46	2SC5013Q	NEC	npn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_c = 35\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 50...100;$ $f_T = 10\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R47	2SC4095R	NEC	npn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_c = 35\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 80...160;$ $f_T = 10\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
R47	2SC5013R	NEC	npn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_c = 35\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 80...160;$ $f_T = 10\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R48	2SC4095S	NEC	npn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_c = 35\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 125...250;$ $f_T = 10\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
R48	2SC5013S	NEC	npn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_c = 35\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 125...250;$ $f_T = 10\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	E•C•E•B
R4s	BFP640	SIEM	npn	$V_{CB0} = 13\text{ В}; I_c = 50\text{ мА}; P_D = 185\text{ мВт}; h_{21} = 110...270;$ $f_T = 40\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	B•E•C•E
R5	2SC4092	NEC	npn	$V_{CB0} = 25\text{ В}; I_c = 70\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 100...200;$ $f_T = 6\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
R5	HSMS-8205	HP	shd x2	$V_{BR} > 4\text{ В}; V_f(I_f = 1\text{ мА}) < 0.35\text{ В}; C_D < 0.26\text{ нФ};$ $R_D = 14\text{ Ом}$	SOT143, TO253	A1•A2•K2•K1
R54	2SC5454	NEC	npn	$V_{CB0} = 9\text{ В}; I_c = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 75...150;$ $f_T = 14.5\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
R54	2SC5750	NEC	npn	$V_{CB0} = 9\text{ В}; I_c = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 75...150;$ $f_T = 15\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	C•E•B•E
R54	2SC5751	NEC	npn	$V_{CB0} = 9\text{ В}; I_c = 50\text{ мА}; P_D = 205\text{ мВт}; h_{21} = 75...150;$ $f_T = 15\text{ ГГц}$	MFPAK-4	E•C•E•B
R54	NE67718	NEC	npn	$V_{CB0} = 9\text{ В}; I_c = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 75...150;$ $f_T = 15\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	C•E•B•E
R54	NE67739	NEC	npn	$V_{CB0} = 9\text{ В}; I_c = 50\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 75...150;$ $f_T = 14.5\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
R54	NE677M04	NEC	npn	$V_{CB0} = 9\text{ В}; I_c = 50\text{ мА}; P_D = 205\text{ мВт}; h_{21} = 75...150;$ $f_T = 15\text{ ГГц}$	MFPAK-4	E•C•E•B
R55	2SC5455	NEC	npn	$V_{CB0} = 9\text{ В}; I_c = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 75...150;$ $f_T = 12\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
R55	2SC5752	NEC	npn	$V_{CB0} = 9\text{ В}; I_c = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 75...150;$ $f_T = 12\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	C•E•B•E
R55	2SC5753	NEC	npn	$V_{CB0} = 9\text{ В}; I_c = 100\text{ мА}; P_D = 205\text{ мВт}; h_{21} = 75...150;$ $f_T = 12\text{ ГГц}$	MFPAK-4	E•C•E•B
R55	NE67818	NEC	npn	$V_{CB0} = 9\text{ В}; I_c = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 75...150;$ $f_T = 12\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	C•E•B•E
R55	NE67839	NEC	npn	$V_{CB0} = 9\text{ В}; I_c = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 75...150;$ $f_T = 12\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
R55	NE678M04	NEC	npn	$V_{CB0} = 9\text{ В}; I_c = 100\text{ мА}; P_D = 205\text{ мВт}; h_{21} = 75...150;$ $f_T = 12\text{ ГГц}$	MFPAK-4	E•C•E•B
R5s	BFP650	SIEM	npn	$V_{CB0} = 13\text{ В}; I_c = 150\text{ мА}; P_D = 500\text{ мВт}; h_{21} = 110...270;$ $f_T = 37\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	B•E•C•E
R66	2SC4091Q	NEC	npn	$V_{CB0} = 15\text{ В}; I_c = 5\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт}; h_{21} = 50...100;$ $f_T > 4\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
R67	2SC4091R	NEC	npn	$V_{CB0} = 15\text{ В}; I_c = 5\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт}; h_{21} = 80...160;$ $f_T > 4\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
R68	2SC4091S	NEC	npn	$V_{CB0} = 15\text{ В}; I_c = 5\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт}; h_{21} = 125...250;$ $f_T > 4\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
R7	HSMS-8207	HP	shd x4	$V_{BR} > 4\text{ В}; V_f(I_f = 1\text{ мА}) < 0.35\text{ В}; C_D < 0.26\text{ нФ};$ $R_D = 14\text{ Ом}$	SOT143, TO253	A1, K4•A2, K1•A3, K2•A4, K3
R8	BFG93A	PHIL	npn	$V_{CB0} = 15\text{ В}; I_c = 35\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 40; f_T > 4.5\text{ ГГц}$	SOT143, TO253	C•B•E•E
R9	HSMS-8209	HP	shd x4	$V_{BR} > 4\text{ В}; V_f(I_f = 1\text{ мА}) < 0.35\text{ В}; C_D < 0.26\text{ нФ};$ $R_D = 14\text{ Ом}$	SOT143, TO253	A1, K4•A2, K3•A3, K1•A4, K2
RA5	BF772	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_c = 80\text{ мА}; P_D = 580\text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T = 8000\text{ МГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
RCs	BFP193	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_c = 80\text{ мА}; P_D = 580\text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T = 8000\text{ МГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E



SOT143/R MW-4
SOT343/R

SC82

SC61



MFPАК-4
TSFP-4

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
RCs	BFP193W	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 80 \text{ мА}; P_D = 580 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T = 8000 \text{ МГц}$	SOT343, SC82A	Е•С•Е•В
RDs	BFP180	SIEM	npn	$V_{CB0} = 10 \text{ В}; I_C = 4 \text{ мА}; P_D = 30 \text{ мВт}; h_{21} = 30...200;$ $f_T = 6200 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
RDs	BFP180W	SIEM	npn	$V_{CB0} = 10 \text{ В}; I_C = 4 \text{ мА}; P_D = 30 \text{ мВт}; h_{21} = 30...200;$ $f_T > 6200 \text{ МГц}$	SOT343, SC82A	Е•С•Е•В
REs	BFP280	SIEM	npn	$V_{CB0} = 10 \text{ В}; I_C = 10 \text{ мА}; P_D = 80 \text{ мВт}; h_{21} = 30...200;$ $f_T > 7000 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
REs	BFP280W	SIEM	npn	$V_{CB0} = 10 \text{ В}; I_C = 10 \text{ мА}; P_D = 80 \text{ мВт}; h_{21} = 30...200;$ $f_T > 7000 \text{ МГц}$	SOT343, SC82A	Е•С•Е•В
RFs	BFP181	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 175 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T = 8000 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
RFs	BFP181R	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 175 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T > 8000 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
RFs	BFP181W	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 175 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T = 8000 \text{ МГц}$	SOT343, SC82A	Е•С•Е•В
RGs	BFP182	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 35 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T > 8000 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
RGs	BFP182R	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 35 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T > 8000 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
RGs	BFP182W	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 35 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T > 8300 \text{ МГц}$	SOT343, SC82A	Е•С•Е•В
RHs	BFP183	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 65 \text{ мА}; P_D = 450 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T = 8000 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
RHs	BFP183R	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 65 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T > 8000 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
RHs	BFP183W	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 65 \text{ мА}; P_D = 450 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T = 8000 \text{ МГц}$	SOT343, SC82A	Е•С•Е•В
RKs	BFP194	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 700 \text{ мВт}; h_{21} = 20...150;$ $f_T = 5000 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
RIIs	BFP196	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 700 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T = 7500 \text{ МГц}$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
RIIs	BFP196W	SIEM	npn	$V_{CB0} = 20 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 700 \text{ мВт}; h_{21} = 50...200;$ $f_T > 7200 \text{ МГц}$	SOT343, SC82A	Е•С•Е•В
S4	BBY62	PHIL	var x2	$V_R < 30 \text{ В}; I_C < 20 \text{ мА}; C_{1B} = 16.5 \text{ нФ}; C_{2B} = 1.6...2 \text{ нФ};$ $C_{1B}/C_{2B} = 8.3$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
S5	BAT15099	SIEM	shd x2	$V_R < 4 \text{ В}; I_C < 110 \text{ мА}; V_F (I_F = 10 \text{ мА}) < 0.32 \text{ В};$ $C_0 < 0.35 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1•A2•K2•A1
S5s	BAT15-099	INF	shd x2	$V_R < 4 \text{ В}; I_C < 110 \text{ мА}; V_F (I_F = 10 \text{ мА}) < 0.41 \text{ В};$ $C_0 < 0.35 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1•A2•K2•A1
S6	BAT15099R	SIEM	shd x4	$V_R < 4 \text{ В}; I_C < 110 \text{ мА}; V_F (I_F = 10 \text{ мА}) < 0.32 \text{ В};$ $C_0 < 0.38 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1, A4•A3, K2•K4, A2•A1, K3
S6s	BAT15-099R	INF	shd x4	$V_R < 4 \text{ В}; I_C < 110 \text{ мА}; V_F (I_F = 10 \text{ мА}) < 0.41 \text{ В};$ $C_0 < 0.35 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1, A4•A3, K2•K4, A2•A1, K3
S7	BAT114-099	SIEM	shd x2	$V_R < 4 \text{ В}; I_C < 90 \text{ мА}; V_F (I_F = 10 \text{ мА}) < 0.8 \text{ В}; I_B = 5 \text{ мкА};$ $C_0 < 0.5 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1•A2•K2•A1
S8	BAT14099R	SIEM	shd x4	$V_R < 4 \text{ В}; I_C < 90 \text{ мА}; V_F (I_F = 10 \text{ мА}) < 0.48 \text{ В}; C_0 < 0.38 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1, A4•A3, K2•K4, A2•A1, K3
S8s	BAT14-099R	INF	shd x4	$V_R < 4 \text{ В}; I_C < 90 \text{ мА}; V_F (I_F = 10 \text{ мА}) < 0.48 \text{ В}; C_0 < 0.38 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	A1, K4•A3, K2•K1, A2•K3, A4
S9	BAT14099	SIEM	shd x2	$V_R < 4 \text{ В}; I_C < 90 \text{ мА}; V_F (I_F = 10 \text{ мА}) < 0.55 \text{ В}; C_0 < 0.35 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	K1•A2•K2•A1
SN	BAT63099R	SIEM	shd x4	$I_C < 50 \text{ мА}; V_F (I_F = 1 \text{ мА}) < 0.3 \text{ В}; C_0 < 1.1 \text{ нФ}$	SOT143, TO253	A3, K1•A4, K2•K3, A2•A1, C4
T5	HSM52865	HP	shd x2	$V_{BR} > 5 \text{ В}; V_F (I_F = 30 \text{ мА}) < 0.6 \text{ В}; C_0 < 0.30 \text{ нФ};$ $P_D = 10 \text{ Ом}$	SOT143, TO253	K1•K2•A2•A1
T78	2SC5507	NEC	npn	$V_{CB0} = 15 \text{ В}; I_C = 12 \text{ мА}; P_D = 39 \text{ мВт}; h_{21} = 50...100;$ $f_T > 20 \text{ ГГц}$	MFPАК-4	Е•С•Е•В
T79	2SC5508	NEC	npn	$V_{CB0} = 15 \text{ В}; I_C = 35 \text{ мА}; P_D = 115 \text{ мВт}; h_{21} = 50...100;$ $f_T > 20 \text{ ГГц}$	MFPАК-4	Е•С•Е•В

MFPK-4
TSFP-4



SC61

SC82

MW-4

SOT143R
SOT343R



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
T8	1SV306	TOSH	var x2	$V_{\beta} > 15 \text{ В}; I_{\beta} (V_{\beta} = 15 \text{ В}) < 0.003 \text{ мкА}; C_{1\beta} = 14 \dots 16 \text{ нФ};$ $C_{10\beta} = 5.5 \dots 6.5 \text{ нФ}$	SC82, USQ	A1•A2•K2•K1
T82	2SC4956	NEC	npn	$V_{\text{СВ}} = 9 \text{ В}; I_{\text{С}} = 10 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 60 \text{ мВт}; h_{21} = 75 \dots 150;$ $f_{\text{T}} = 12 \text{ ГГц}$	SC61, MPAK-4	С•Е•В•Е
T82	2SC5014	NEC	npn	$V_{\text{СВ}} = 9 \text{ В}; I_{\text{С}} = 10 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 60 \text{ мВт}; h_{21} = 75 \dots 150;$ $f_{\text{T}} = 12 \text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	Е•С•Е•В
T83	2SC4957	NEC	npn	$V_{\text{СВ}} = 9 \text{ В}; I_{\text{С}} = 30 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 180 \text{ мВт}; h_{21} = 75 \dots 150;$ $f_{\text{T}} = 12 \text{ ГГц}$	SC61, MPAK-4	С•Е•В•Е
T83	2SC5015	NEC	npn	$V_{\text{СВ}} = 9 \text{ В}; I_{\text{С}} = 30 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 75 \dots 150;$ $f_{\text{T}} = 12 \text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	Е•С•Е•В
T84	2SC5178	NEC	npn	$V_{\text{СВ}} = 5 \text{ В}; I_{\text{С}} = 10 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 30 \text{ мВт}; h_{21} = 70 \dots 140;$ $f_{\text{T}} > 10.5 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
T84	2SC5180	NEC	npn	$V_{\text{СВ}} = 5 \text{ В}; I_{\text{С}} = 10 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 30 \text{ мВт}; h_{21} = 70 \dots 140;$ $f_{\text{T}} > 10 \text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	Е•С•Е•В
T86	2SC5183	NEC	npn	$V_{\text{СВ}} = 5 \text{ В}; I_{\text{С}} = 30 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 90 \text{ мВт}; h_{21} = 70 \dots 140;$ $f_{\text{T}} > 9.5 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
T88	2SC5192	NEC	npn	$V_{\text{СВ}} = 9 \text{ В}; I_{\text{С}} = 100 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 200 \text{ мВт}; h_{21} = 80 \dots 160;$ $f_{\text{T}} > 4 \text{ ГГц}$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
T89	2SC5288	NEC	npn	$V_{\text{СВ}} = 9 \text{ В}; I_{\text{С}} = 150 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 60$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
T90	2SC5289	NEC	npn	$V_{\text{СВ}} = 9 \text{ В}; I_{\text{С}} = 300 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 200 \text{ мВт}; h_{21} > 60$	SOT143, TO253	С•Е•В•Е
TC	2SC2736	REN	npn	$V_{\text{СВ}} = 30 \text{ В}; I_{\text{С}} = 50 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 30 \dots 200;$ $f_{\text{T}} > 1400 \text{ МГц}$	SOT343, SC82A	Е•В•С•п.с.
TI	2SC4197	REN	npn	$V_{\text{СВ}} = 25 \text{ В}; I_{\text{С}} = 50 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 150 \text{ мВт}; h_{21} = 50 \dots 180;$ $f_{\text{T}} > 3 \text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	Е•В•С•п.с.
TV	JDV4P08U	TOSH	var x2	$V_{\beta} < 10 \text{ В}; I_{\beta} < 0.003 \text{ мкА}; C_{1\beta} = 17.3 \dots 19.3 \text{ нФ};$ $C_{4\beta} = 5.3 \dots 6.6$	SOT343, SC82A	A1•A2•K2•K1
U1A	3SK230UAA	NEC	dmMOS	$V_{\text{DS}} = 18 \text{ В}; I_{\text{D}} = 25 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 200 \text{ мВт}; g_{\text{T}} > 16 \text{ мСм};$ $I_{\text{DSS}} = 0.01 \dots 0.3 \text{ мА}$	SC61, MPAK-4	С•Д•G2•G1
U1B	3SK230UAB	NEC	dmMOS	$V_{\text{DS}} = 18 \text{ В}; I_{\text{D}} = 25 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 200 \text{ мВт}; g_{\text{T}} > 16 \text{ мСм};$ $I_{\text{DSS}} = 0.01 \dots 0.3 \text{ мА}$	SC61, MPAK-4	С•Д•G2•G1
U1C	3SK231C	NEC	dmMESFET	$V_{\text{DS}} = 18 \text{ В}; I_{\text{D}} = 25 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 200 \text{ мВт}; I_{\text{DSS}} = 0.01 \dots 10 \text{ мА}$	SOT143, TO253	С•Д•G2•G1
U1D	3SK231D	NEC	dmMESFET	$V_{\text{DS}} = 18 \text{ В}; I_{\text{D}} = 25 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 200 \text{ мВт}; I_{\text{DSS}} = 0.01 \dots 10 \text{ мА}$	SC61, MPAK-4	С•Д•G2•G1
U1E	3SK252UAE	NEC	dmMOS	$V_{\text{DS}} = 18 \text{ В}; I_{\text{D}} = 25 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 200 \text{ мВт}; g_{\text{T}} > 14 \text{ мСм};$ $I_{\text{DSS}} = 0.1 \dots 5 \text{ мА}$	SC61, MPAK-4	С•Д•G2•G1
U1E	3SK254U1E	NEC	dmMOS	$V_{\text{DS}} = 18 \text{ В}; I_{\text{D}} = 25 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 130 \text{ мВт}; g_{\text{T}} > 14 \text{ мСм};$ $I_{\text{DSS}} = 0.1 \dots 0.5 \text{ мА}$	SOT343, SC82A	С•Д•G2•G1
U1G	3SK253UAG	NEC	dmMOS	$V_{\text{DS}} = 18 \text{ В}; I_{\text{D}} = 25 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 200 \text{ мВт}; g_{\text{T}} > 14 \text{ мСм};$ $I_{\text{DSS}} = 0.5 \dots 7 \text{ мА}$	SC61, MPAK-4	С•Д•G2•G1
U1G	3SK255U1G	NEC	dmMOS	$V_{\text{DS}} = 18 \text{ В}; I_{\text{D}} = 25 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 130 \text{ мВт}; g_{\text{T}} > 14 \text{ мСм};$ $I_{\text{DSS}} = 0.1 \dots 7 \text{ мА}$	SOT343, SC82A	С•Д•G2•G1
U1s	BGX50A	INF	di x4	$V_{\beta} < 50 \text{ В}; I_{\beta} < 140 \text{ мА}; V_{\beta} (I_{\beta} = 100 \text{ мА}) < 1.3 \text{ В};$ $I_{\beta} < 0.2 \text{ мкА}; C_{\beta} < 1.5 \text{ нФ}; f_{\text{тср}} < 6 \text{ нс}$	SOT143, TO253	K1, K2•K4, A1•A4, A3•A2, K3
U55	3SK134UEE	NEC	dmMOS	$V_{\text{DS}} = 18 \text{ В}; I_{\text{D}} = 25 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 200 \text{ мВт}; g_{\text{T}} > 25 \text{ мСм};$ $I_{\text{DSS}} = 0.4 \dots 5 \text{ мА}$	SC61, MPAK-4	С•Д•G2•G1
U55	3SK245	NEC	dmMESFET	$V_{\text{DS}} = 18 \text{ В}; I_{\text{D}} = 25 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 130 \text{ мВт}; I_{\text{DSS}} = 0.4 \dots 8 \text{ мА}$	SOT343, SC82A	С•Д•G2•G1
U56	3SK134UEF	NEC	dmMOS	$V_{\text{DS}} = 18 \text{ В}; I_{\text{D}} = 25 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 200 \text{ мВт}; g_{\text{T}} > 25 \text{ мСм};$ $I_{\text{DSS}} = 3 \dots 8 \text{ мА}$	SC61, MPAK-4	С•Д•G2•G1
U56	3SK245	NEC	dmMESFET	$V_{\text{DS}} = 18 \text{ В}; I_{\text{D}} = 25 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 130 \text{ мВт}; I_{\text{DSS}} = 0.4 \dots 8 \text{ мА}$	SOT343, SC82A	С•Д•G2•G1
U65	3SK135ALS	NEC	dmMOS	$V_{\text{DS}} = 20 \text{ В}; I_{\text{D}} = 25 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 200 \text{ мВт}; g_{\text{T}} > 14 \text{ мСм};$ $I_{\text{DSS}} = 0.01 \dots 2 \text{ мА}$	SC61, MPAK-4	С•Д•G2•G1
U66	3SK135AKS	NEC	dmMOS	$V_{\text{DS}} = 20 \text{ В}; I_{\text{D}} = 25 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 200 \text{ мВт}; g_{\text{T}} > 14 \text{ мСм};$ $I_{\text{DSS}} = 1 \dots 6 \text{ мА}$	SC61, MPAK-4	С•Д•G2•G1
U7	3SK320	TOSH	dmMESFET	$V_{\text{DS}} = 6 \text{ В}; I_{\text{D}} = 18 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 100 \text{ мВт}; g_{\text{T}} = 22 \text{ мСм}$	SC82, USQ	G1•G2•D•S
U71	3SK177U71	NEC	dmMESFET	$V_{\text{DS}} = 13 \text{ В}; I_{\text{D}} = 40 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 200 \text{ мВт}; g_{\text{T}} > 18 \text{ мСм};$ $I_{\text{DSS}} = 5 \dots 15 \text{ мА}$	SC61, MPAK-4	С•Д•G2•G1
U71	3SK299	NEC	dmMESFET	$V_{\text{DS}} = 13 \text{ В}; I_{\text{D}} = 40 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 120 \text{ мВт}; g_{\text{T}} > 18 \text{ мСм};$ $I_{\text{DSS}} = 5 \dots 15 \text{ мА}$	SOT343, SC82A	С•Д•G2•G1
U72	3SK177U72	NEC	dmMESFET	$V_{\text{DS}} = 13 \text{ В}; I_{\text{D}} = 40 \text{ мА}; P_{\text{D}} = 200 \text{ мВт}; g_{\text{T}} > 18 \text{ мСм};$ $I_{\text{DSS}} = 10 \dots 25 \text{ мА}$	SC61, MPAK-4	С•Д•G2•G1



SOT143/R MW-4
SOT343/R



SC82



SC61



MFP4K-4
TSFP-4

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
U72	3SK299	NEC	dnMESFET	$V_{DS} = 13\text{ В}; I_D = 40\text{ мА}; P_D = 120\text{ мВт}; g_f > 18\text{ мСм}; I_{DSS} = 10...25\text{ мА}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U72	NE25118	NEC	nMESFET	$GaAs; V_{DS} = 13\text{ В}; I_D = 40\text{ мА}; P_D = 120\text{ мВт}; g_f = 25\text{ мСм}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U73	3SK177U73	NEC	dnMESFET	$V_{DS} = 13\text{ В}; I_D = 40\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f > 18\text{ мСм}; I_{DSS} = 20...35\text{ мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U73	3SK299	NEC	dnMESFET	$V_{DS} = 13\text{ В}; I_D = 40\text{ мА}; P_D = 120\text{ мВт}; g_f > 18\text{ мСм}; I_{DSS} = 20...35\text{ мА}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U73	NE25118	NEC	nMESFET	$GaAs; V_{DS} = 13\text{ В}; I_D = 40\text{ мА}; P_D = 120\text{ мВт}; g_f = 25\text{ мСм}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U74	3SK177U74	NEC	dnMESFET	$V_{DS} = 13\text{ В}; I_D = 40\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f > 18\text{ мСм}; I_{DSS} = 30...40\text{ мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U74	3SK299	NEC	dnMESFET	$V_{DS} = 13\text{ В}; I_D = 40\text{ мА}; P_D = 120\text{ мВт}; g_f > 18\text{ мСм}; I_{DSS} = 30...40\text{ мА}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U74	NE25118	NEC	nMESFET	$GaAs; V_{DS} = 13\text{ В}; I_D = 40\text{ мА}; P_D = 120\text{ мВт}; g_f = 25\text{ мСм}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U76	3SK206	NEC	dnMESFET	$V_{DS} = 10\text{ В}; I_D = 80\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f > 25\text{ мСм}; I_{DSS} = 10...25\text{ мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U77	3SK206	NEC	dnMESFET	$V_{DS} = 10\text{ В}; I_D = 80\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f > 25\text{ мСм}; I_{DSS} = 20...35\text{ мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U78	3SK206	NEC	dnMESFET	$V_{DS} = 10\text{ В}; I_D = 80\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f > 25\text{ мСм}; I_{DSS} = 30...50\text{ мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U79	3SK206	NEC	dnMESFET	$V_{DS} = 10\text{ В}; I_D = 80\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f > 25\text{ мСм}; I_{DSS} = 45...80\text{ мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U87	3SK176AUHG	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 18\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f > 22\text{ мСм}; I_{DSS} = 1...6\text{ мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U88	3SK176AUHH	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 18\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f > 22\text{ мСм}; I_{DSS} = 4...10\text{ мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U90	3SK223UIO	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 18\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f > 15\text{ мСм}; I_{DSS} = 0.01...3\text{ мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U90	3SK243	NEC	dnMESFET	$V_{DS} = 18\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; I_{DSS} = 0.01...8\text{ мА}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U91	3SK223UIA	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 18\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f > 15\text{ мСм}; I_{DSS} = 1...8\text{ мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U91	3SK243	NEC	dnMESFET	$V_{DS} = 18\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; I_{DSS} = 0.01...8\text{ мА}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U94	3SK224UID	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 18\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f > 18\text{ мСм}; I_{DSS} = 0.5...7\text{ мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U94	3SK244D	NEC	dnMESFET	$V_{DS} = 18\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 130\text{ мВт}; I_{DSS} = 0.5...15\text{ мА}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
U95	3SK224UIE	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 18\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f > 18\text{ мСм}; I_{DSS} = 5...15\text{ мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
U95	3SK244E	NEC	dnMESFET	$V_{DS} = 18\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 130\text{ мВт}; I_{DSS} = 0.5...15\text{ мА}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
UF	3SK293	TOSH	dnMOS	$V_{DS} = 12.5\text{ В}; I_D = 30\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; g_f > 22\text{ мСм}; I_{DSS} < 0.1\text{ мА}$	SC82, USQ	D•S•G1•G2
UHGR	3SK260GR	TOSH	dnMOS	$V_{DS} = 13.5\text{ В}; I_D = 30\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; g_f = 27\text{ мСм}; I_{DSS} = 6...14\text{ мА}$	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UHY	3SK260Y	TOSH	dnMOS	$V_{DS} = 13.5\text{ В}; I_D = 30\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; g_f = 27\text{ мСм}; I_{DSS} = 3...7\text{ мА}$	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UI	3SK259	TOSH	dnMOS	$V_{DS} = 13.5\text{ В}; I_D = 30\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; g_f = 21\text{ мСм}; I_{DSS} < 2\text{ мА}$	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UK	3SK294	TOSH	dnMOS	$V_{DS} = 12.5\text{ В}; I_D = 30\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; g_f > 19.5\text{ мСм}; I_{DSS} < 0.1\text{ мА}$	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UN	3SK274	TOSH	dnMESFET	$V_{DS} = 9\text{ В}; I_D = 20\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; I_{DSS} = 0.4...8\text{ мА}; g_f = 19\text{ мСм}$	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UO	3SK249	TOSH	dnMOS	$V_{DS} = 12.5\text{ В}; I_D = 30\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; g_f > 17\text{ мСм}; I_{DSS} = 0.01...3\text{ мА}$	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UR	3SK256	TOSH	dnMOS	$V_{DS} = 13.5\text{ В}; I_D = 30\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; g_f = 21.5\text{ мСм}; I_{DSS} < 0.1\text{ мА}$	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UT	3SK257	TOSH	dnMOS	$V_{DS} = 13.5\text{ В}; I_D = 30\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; g_f = 21\text{ мСм}$	SC82, USQ	G1•G2•D•S
UU	3SK258	TOSH	dnMOS	$V_{DS} = 13.5\text{ В}; I_D = 30\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; g_f = 13\text{ мСм}; I_{DSS} < 0.1\text{ мА}$	SC82, USQ	G1•G2•D•S
V11	3SK131	NEC	dnMOS	$V_{DS} = 20\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; g_f > 22\text{ мСм}; I_{DSS} = 7...13\text{ мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1

MFPAK-4
TSFP-4



SC61
1 1 4
2 2 3 3

SC82
1 1 4
2 2 3 3

MW-4
1 1 4
2 2 3 3

SOT143R
SOT343R



Код	Типономиннал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3*4
V11	3SK242	NEC	dmMOS	$V_{DS} = 20\text{В}; I_D = 25\text{мА}; P_D = 130\text{мВт}; I_{BSS} = 7...25\text{мА}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
V12	3SK131	NEC	dmMOS	$V_{DS} = 20\text{В}; I_D = 25\text{мА}; P_D = 200\text{мВт}; G_e > 22\text{мСМ}; I_{BSS} = 11...19\text{мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
V12	3SK242	NEC	dmMOS	$V_{DS} = 20\text{В}; I_D = 25\text{мА}; P_D = 130\text{мВт}; I_{BSS} = 7...25\text{мА}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
V12	BFG67/X	PHIL	nnpn	$V_{CB0} = 10\text{В}; I_C = 50\text{мА}; P_D = 300\text{мВт}; h_{21} > 60; f_T > 8\text{ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
V13	3SK131	NEC	dmMOS	$V_{DS} = 20\text{В}; I_D = 25\text{мА}; P_D = 200\text{мВт}; G_e > 22\text{мСМ}; I_{BSS} = 17...25\text{мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
V13	3SK242	NEC	dmMOS	$V_{DS} = 20\text{В}; I_D = 25\text{мА}; P_D = 130\text{мВт}; I_{BSS} = 7...25\text{мА}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
V13	BFG197/X	PHIL	nnpn	$V_{CB0} = 20\text{В}; I_C = 100\text{мА}; P_D = 350\text{мВт}; h_{21} > 40; f_T = 7.5\text{ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
V15	BFG93A/X	PHIL	nnpn	$V_{CB0} = 15\text{В}; I_C = 35\text{мА}; P_D = 300\text{мВт}; h_{21} > 40; f_T > 4.5\text{ГГц}$	SOT143, TO253	C•E•B•E
V21	3SK222VBA	NEC	dmMOS	$V_{DS} = 18\text{В}; I_D = 25\text{мА}; P_D = 200\text{мВт}; G_e > 15\text{мСМ}; I_{BSS} = 0.01...3\text{мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
V21	3SK246	NEC	dmMOS	$V_{DS} = 20\text{В}; I_D = 25\text{мА}; P_D = 130\text{мВт}; I_{BSS} = 0.01...8\text{мА}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
V22	3SK222VBB	NEC	dmMOS	$V_{DS} = 18\text{В}; I_D = 25\text{мА}; P_D = 200\text{мВт}; G_e > 15\text{мСМ}; I_{BSS} = 1...8\text{мА}$	SC61, MPAK-4	S•D•G2•G1
V22	3SK246	NEC	dmMOS	$V_{DS} = 20\text{В}; I_D = 25\text{мА}; P_D = 130\text{мВт}; I_{BSS} = 0.01...8\text{мА}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
V26	BFG67/XR	PHIL	nnpn	$V_{CB0} = 10\text{В}; I_C = 50\text{мА}; P_D = 300\text{мВт}; h_{21} > 60; f_T > 8\text{ГГц}$	SOT143R	C•E•B•E
V3	BFG67	VIS	nnpn	$V_{CB0} = 10\text{В}; I_C = 50\text{мА}; P_D = 300\text{мВт}; h_{21} > 60; f_T > 8\text{ГГц}$	SOT143, TO253	C•B•E•E
V3	BFG67	PHIL	nnpn	$V_{CB0} = 10\text{В}; I_C = 50\text{мА}; P_D = 300\text{мВт}; h_{21} > 60; f_T > 8\text{ГГц}$	SOT143, TO253	C•B•E•E
V35	BFG197A/XR	PHIL	nnpn	$V_{CB0} = 20\text{В}; I_C = 100\text{мА}; P_D = 350\text{мВт}; h_{21} > 40; f_T = 7.5\text{ГГц}$	SOT143R	C•E•B•E
V5	BFG197	PHIL	nnpn	$V_{CB0} = 20\text{В}; I_C = 100\text{мА}; P_D = 350\text{мВт}; h_{21} > 40; f_T = 7.5\text{ГГц}$	SOT143, TO253	C•B•E•E
VH-	2SC5624	REN	nnpn	$V_{CB0} = 10\text{В}; I_C = 35\text{мА}; P_D = 100\text{мВт}; h_{21} = 80...160; f_T > 25\text{ГГц}$	SOT343, SC82A	B•E•C•E
VI	2SC4229	REN	nnpn	$V_{CB0} = 30\text{В}; I_C = 20\text{мА}; P_D = 150\text{мВт}; h_{21} = 50...180; f_T > 700\text{МГц}$	SOT343, SC82A	E•B•C•n.c.
W0F	TSDF1205RW	TELEF	nnpn	$V_{CB0} = 9\text{В}; I_C = 12\text{мА}; P_D = 40\text{мВт}; h_{21} = 50...250; f_T = 12\text{ГГц}$	SOT343R	C•E•B•E
W18	BFP181TW	TELEF	nnpn	$V_{CB0} = 15\text{В}; I_C = 20\text{мА}; P_D = 160\text{мВт}; h_{21} = 50...150; f_T = 8\text{ГГц}$	SOT343, SC82A	C•E•B•E
W22	S822TW	VISH	nnpn	$V_{CB0} = 12\text{В}; I_C = 8\text{мА}; P_D = 30\text{мВт}; h_{21} = 40...150; f_T = 5.2\text{ГГц}$	SOT343, SC82A	E•C•E•B
W28	BFP280TW	TELEF	nnpn	$V_{CB0} = 15\text{В}; I_C = 10\text{мА}; P_D = 80\text{мВт}; h_{21} = 50...150; f_T = 7\text{ГГц}$	SOT343, SC82A	C•E•B•E
W2F	TSDF1220RW	TELEF	nnpn	$V_{CB0} = 9\text{В}; I_C = 40\text{мА}; P_D = 200\text{мВт}; h_{21} = 50...150; f_T = 12\text{ГГц}$	SOT343R	C•E•B•E
W4s	BCR400R	INF	abc	$V_{CC} < 18\text{В}; I_{SMIN} = 0.1\text{мА}$	SOT143, TO253	GND•CONTR•VS•REXT
W4s	BCR400W	INF	abc	$V_{CC} < 18\text{В}; I_{SMIN} = 0.1\text{мА}$	SOT343, SC82A	GND•CONTR•VS•REXT
W67	BFP67W	TELEF	nnpn	$V_{CB0} = 20\text{В}; I_C = 50\text{мА}; P_D = 200\text{мВт}; h_{21} = 65...150; f_T = 7.5\text{ГГц}$	SOT343, SC82A	C•E•B•E
W82	BFP182TW	TELEF	nnpn	$V_{CB0} = 15\text{В}; I_C = 35\text{мА}; P_D = 200\text{мВт}; h_{21} = 50...150; f_T = 7.5\text{ГГц}$	SOT343, SC82A	C•E•B•E
W83	BFP183TW	TELEF	nnpn	$V_{CB0} = 15\text{В}; I_C = 65\text{мА}; P_D = 200\text{мВт}; h_{21} = 50...150; f_T = 8\text{ГГц}$	SOT343, SC82A	C•E•B•E
W92	BFP92AW	TELEF	nnpn	$V_{CB0} = 20\text{В}; I_C = 30\text{мА}; P_D = 200\text{мВт}; h_{21} = 50...150; f_T = 6\text{ГГц}$	SOT343, SC82A	C•E•B•E
WF0	TSDF1205W	TELEF	nnpn	$V_{CB0} = 9\text{В}; I_C = 12\text{мА}; P_D = 40\text{мВт}; h_{21} = 50...250; f_T = 12\text{ГГц}$	SOT343, SC82A	C•E•B•E
WF2	TSDF1220W	TELEF	nnpn	$V_{CB0} = 9\text{В}; I_C = 40\text{мА}; P_D = 200\text{мВт}; h_{21} = 50...150; f_T = 12\text{ГГц}$	SOT343, SC82A	C•E•B•E
WFE	BFP93A	TELEF	nnpn	$V_{CB0} = 20\text{В}; I_C = 50\text{мА}; P_D = 300\text{мВт}; h_{21} = 50...200; f_T = 6\text{ГГц}$	SOT343, SC82A	E•C•E•B
WH-	2SC5623	REN	nnpn	$V_{CB0} = 10\text{В}; I_C = 12\text{мА}; P_D = 50\text{мВт}; h_{21} = 60...140; f_T > 23\text{ГГц}$	SOT343, SC82A	B•E•C•E



SOT143/R **MW-4**
SOT343/R

SC82

SC61



MFP4K-4
TSFP-4

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
WI	3SK197	REN	nMOS	$V_{DS} = 12\text{ В}; I_D = 35\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G = 24.6\text{ дБ};$ $NF = 5.5\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
WJ-	2SC5894	REN	npn	$V_{CE0} = 12\text{ В}; I_C = 12\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт}; h_{21} = 70...150;$ $f_T > 16\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	B•E•C•E
WMO	BFP998RW	VIS	dnMOS	$V_{DS} = 12\text{ В}; I_D = 30\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; I_{DS} = 4...18\text{ мА};$ $g_F > 21\text{ мСм}$	SOT343R	S•D•G2•G1
WSE	BFP280TRW	TELEF	npn	$V_{CE0} = 15\text{ В}; I_C = 10\text{ мА}; P_D = 80\text{ мВт}; h_{21} = 50...150;$ $f_T = 7\text{ ГГц}$	SOT343R	C•E•B•E
WSF	BFP181TRW	TELEF	npn	$V_{CE0} = 15\text{ В}; I_C = 20\text{ мА}; P_D = 160\text{ мВт}; h_{21} = 50...150;$ $f_T = 8\text{ ГГц}$	SOT343R	C•E•B•E
WSF	S822TRW	VISH	npn	$V_{CE0} = 12\text{ В}; I_C = 8\text{ мА}; P_D = 30\text{ мВт}; h_{21} = 40...150;$ $f_T = 5.2\text{ ГГц}$	SOT343R	E•C•E•B
WSG	BFP182TRW	TELEF	npn	$V_{CE0} = 15\text{ В}; I_C = 35\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 50...150;$ $f_T = 7.5\text{ ГГц}$	SOT343R	C•E•B•E
WSH	BFP183TRW	TELEF	npn	$V_{CE0} = 15\text{ В}; I_C = 65\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 50...150;$ $f_T = 8\text{ ГГц}$	SOT343R	C•E•B•E
XB	2SC4416	REN	npn	$V_{CE0} = 25\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 50...180;$ $f_T > 3000\text{ МГц}$	SOT343, SC82A	B•E•C•n.c.
XC	2SC4415	REN	npn	$V_{CE0} = 30\text{ В}; I_C = 20\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 50...180;$ $f_T > 700\text{ МГц}$	SOT343, SC82A	C•B•E•B
XE	2SK1092	REN	nFET	GaAs; $V_{DS} = 4\text{ В}; I_D = 150\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G > 8\text{ дБ};$ $NF < 3.5\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•n.c. • G
XI	3SK196	REN	nMOS	$V_{DS} = 12\text{ В}; I_D = 35\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G = 32\text{ дБ};$ $NF = 1.0\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
XM	2SC4591	REN	npn	$V_{CE0} = 15\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 40...250;$ $f_T > 6500\text{ МГц}$	SOT343, SC82A	E•B•C•n.c.
XN	2SC4592	REN	npn	$V_{CE0} = 15\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 40...250;$ $f_T > 7000\text{ МГц}$	SOT343, SC82A	C•E•B•E
XR	3SK228	REN	nFET	GaAs; $V_{DS} = 12.0\text{ В}; I_D = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G > 17\text{ дБ};$ $NF < 2.0\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
XS	3SK229	REN	nFET	GaAs; $V_{DS} = 12.0\text{ В}; I_D = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; P_G > 17\text{ дБ};$ $NF < 2.0\text{ дБ}$	SOT343, SC82A	S•D•G2•G1
XV	2SC4680	REN	npn	$V_{CE0} = 12\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 100;$	SOT343, SC82A	E•B•C•n.c.
XV-	3SK309	REN	dnMESFET	$V_{DS} = 6\text{ В}; I_D = 18\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; g_F > 30\text{ мСм}$	SOT343, SC82A	S•G1 • G2 • D
YB-	3SK313	REN	dnMOS	$V_{DS} = 6\text{ В}; I_D = 20\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; g_F > 18\text{ мСм}$	SOT343, SC82A	S•G1 • G2 • D
YB-	3SK319	REN	dnMOS	$V_{DS} = 6\text{ В}; I_D = 20\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; g_F > 18\text{ мСм}$	SC61, MPAK-4	S•G1 • G2 • D
YJ-	2SC4900	REN	npn	$V_{CE0} = 15\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 50...250;$ $f_T > 6\text{ ГГц}$	SC61, MPAK-4	C•E•B•E
ZD-	2SC5080	REN	npn	$V_{CE0} = 15\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 50...160;$ $f_T > 10.5\text{ ГГц}$	SC61, MPAK-4	E•C•E•B
ZD-	2SC5081	REN	npn	$V_{CE0} = 15\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; h_{21} = 50...160;$ $f_T > 10.5\text{ ГГц}$	SOT343, SC82A	E•C•E•B
ZP-	3SK297	REN	dnMOS	$V_{DS} = 12\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; g_F > 16\text{ мСм};$ $I_{DSS} = 0.5...10\text{ мА}$	SC61, MPAK-4	S•G1 • G2 • D
ZP-	3SK298	REN	dnMOS	$V_{DS} = 12\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; g_F > 16\text{ мСм};$ $I_{DSS} = 0.5...10\text{ мА}$	SOT343, SC82A	S•G1 • G2 • D
ZQ-	3SK295	REN	dnMOS	$V_{DS} = 12\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; g_F > 16\text{ мСм};$ $I_{DSS} = 0.5...10\text{ мА}$	SC61, MPAK-4	S•G1 • G2 • D
ZQ-	3SK296	REN	dnMOS	$V_{DS} = 12\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; g_F > 16\text{ мСм};$ $I_{DSS} = 0.5...10\text{ мА}$	SOT343, SC82A	S•G1 • G2 • D
ZR-	3SK300	REN	dnMOS	$V_{DS} = 14\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; g_F > 20\text{ мСм}$	SC61, MPAK-4	S•G1 • G2 • D
ZR-	3SK317	REN	dnMOS	$V_{DS} = 14\text{ В}; I_D = 25\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; g_F > 20\text{ мСм}$	SOT343, SC82A	S•G1 • G2 • D
ZS-	2SC5545	REN	npn	$V_{CE0} = 15\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} = 80...160;$ $f_T > 10\text{ ГГц}$	SC61, MPAK-4	B•C•E•C

SOT553

SOT353
SC88ASOT23-5
TSOT23-5

SOT23-5, SOT353/553...

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
#CGA	AD7415ARTZ	AD	dts	10-паар.; SMBus/°C; $V_{DD}=2.7...5.5$ В	SOT23-5	AS•GND•VDD•SDA•SCL
#CGB	AD7415ARTZ	AD	dts	10-паар.; SMBus/°C; $V_{DD}=2.7...5.5$ В	SOT23-5	AS•GND•VDD•SDA•SCL
0J	MC33464N-20CTR	ON	mic	$V_{IR}=2.0$ В; $V_{IN}=0.7...10$ В	SOT23-5	RES•IN•GND•n.c.•n.c.
0K	MC33464N-30CTR	ON	mic	$V_{IR}=3.0$ В; $V_{IN}=0.7...10$ В	SOT23-5	RES•IN•GND•n.c.•n.c.
0R	MC33464N-20ATR	ON	mic	$V_{IR}=2.0$ В; $V_{IN}=0.7...10$ В	SOT23-5	RES•IN•GND•n.c.•n.c.
0S	MC33464N-30ATR	ON	mic	$V_{IR}=3.0$ В; $V_{IN}=0.7...10$ В	SOT23-5	RES•IN•GND•n.c.•n.c.
1R	MC33464N-21ATR	ON	mic	$V_{IR}=2.1$ В; $V_{IN}=0.7...10$ В	SOT23-5	RES•IN•GND•n.c.•n.c.
21	RN47A1	TOSH	Dnnp/npn	$V_{CE0}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=200$ мВт; $f_T=250$ МГц; $R_1=4.7$ кОм	SOT353, SC88A	E1•B1•E2•C2•C1, B2
22	RN47A2	TOSH	Dnnp/npn	$V_{CE0}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=200$ мВт; $f_T=250$ МГц; $R_1=22$ кОм	SOT353, SC88A	E1•B1•E2•C2•C1, B2
23	RN47A3	TOSH	Dnnp/npn	$V_{CE0}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=200$ мВт; $f_T=250$ МГц; $R_1=10$ кОм	SOT353, SC88A	E1•B1•E2•C2•C1, B2
24	RN47A4	TOSH	Dnnp/npn	$V_{CE0}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=200$ мВт; Q1: $R_1/R_2=47$ кОм/47 кОм; Q2: $R_1/R_2=10$ кОм/47 кОм	SOT353, SC88A	E1•B1•E2•C2•C1, B2
25	RN47A5	TOSH	Dnnp/npn	$V_{CE0}=50$ В; $I_C=100$ мА; $P_D=200$ мВт; Q1: $R_1/R_2=47$ кОм/47 кОм; Q2: $R_1/R_2=4.7$ кОм/10 кОм	SOT353, SC88A	E1•B1•E2•C2•C1, B2
44A	RN1544A	TOSH	Dnnp x2	$V_{CE0}=50$ В; $I_C=300$ мА; $P_D=300$ мВт; $I_{B1}=200...700$; $f_T=30$ МГц; $R_1=2.2$ кОм	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
44B	RN1544B	TOSH	Dnnp x2	$V_{CE0}=50$ В; $I_C=300$ мА; $P_D=300$ мВт; $I_{B1}=350...1200$; $f_T=30$ МГц; $R_1=2.2$ кОм	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
5L	MC33464N-45CTR	ON	mic	$V_{IR}=4.5$ В; $V_{IN}=0.7...10$ В	SOT23-5	RES•IN•GND•n.c.•n.c.
5T	MC33464N-45ATR	ON	mic	$V_{IR}=4.5$ В; $V_{IN}=0.7...10$ В	SOT23-5	RES•IN•GND•n.c.~n.c.
7J	MC33464N-27CTR	ON	mic	$V_{IR}=2.7$ В; $V_{IN}=0.7...10$ В	SOT23-5	RES•IN•GND•n.c.~n.c.
7R	MC33464N-27ATR	ON	mic	$V_{IR}=2.7$ В; $V_{IN}=0.7...10$ В	SOT23-5	RES•IN•GND•n.c.~n.c.
7Z25	NCT5Z125MSX	FAIR	3-stbuff	$V_{OC}=1.65...5.5$ В; $I_{OUT}=±24$ мА	SOT23-5	OE•A•GND•Y•VCC
8T	MC33464N-48ATR	ON	mic	$V_{IR}=4.8$ В; $V_{IN}=0.7...10$ В	SOT23-5	RES•IN•GND•n.c.~n.c.
9F	MC33464N-09CTR	ON	mic	$V_{IR}=0.9$ В; $V_{IN}=0.7...10$ В	SOT23-5	RES•IN•GND•n.c.~n.c.
9N	MC33464N-09ATR	ON	mic	$V_{IR}=0.9$ В; $V_{IN}=0.7...10$ В	SOT23-5	RES•IN•GND•n.c.~n.c.
A03	OPA703NA	TI	OA	R-R; $V_{DD}=4...12/±2...±6$ В; $f_{BD}=1$ МГц; $I_S=300$ мкА; $V_{OS} < ±0.75$ мВ	SOT23-5	OUT•V-•+IN•-IN•V+
A04	OPA704NA	TI	OA	R-R; $V_{DD}=4...12/±2...±6$ В; $f_{BD}=3$ МГц; $I_S=300$ мкА; $V_{OS} < ±0.75$ мВ	SOT23-5	OUT•V-•+IN•-IN•V+
A05	OPA705NA	TI	OA	R-R; $V_{DD}=4...12/±2...±6$ В; $f_{BD}=1$ МГц; $I_S=250$ мкА; $V_{OS} < ±5$ мВ	SOT23-5	OUT•V-•+IN•-IN•V+
A0N	AD8565AKSZ	AD	OA	$f_{BD}=5$ МГц; $P_D=12$ мВт; $V_{DD}=4.5...16$ В	SOT353, SC88A	OUT•V+•+IN•-IN•V-
A0P	AD8531ARTZ	AD	OA	$f_{BD}=3$ МГц; $P_D=6$ мВт; $V_{DD}=2.7...6$ В	SOT23-5	OUT•A•V-•+IN•A•-IN•A•V+
A0Q	AD8531AKSZ	AD	OA	$f_{BD}=3$ МГц; $P_D=6$ мВт; $V_{DD}=2.7...6$ В	SOT353, SC88A	OUT•A•V-•+IN•A•-IN•A•V+
A1	1SS308	TOSH	di x4	$V_F < 80$ В; $I_C < 300$ мА; $V_F (I_F=100$ мА) < 1.2 В; $I_R < 0.5$ мкА; $IRR < 4$ нс	SOT23-5	K1•A•K2•K3•K4
A1	FMA1A	ROHM	Dnnp x2	$V_{CE0}=50$ В; $I_{CM}=100$ мА; $P_D=300$ мВт; $h_{21} > 56$; 22 кОм/22 кОм	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
A1	UMA1N	ROHM	Dnnp x2	$V_{CE0}=50$ В; $I_{CM}=100$ мА; $P_D=150$ мВт; $h_{21} > 56$; 22 кОм/22 кОм	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A10	FMA10A	ROHM	Dnnp x2	$V_{CE0}=50$ В; $I_{CM}=100$ мА; $P_D=300$ мВт; $h_{21} > 56$; $R2/R1=10$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
A10	FMA9A	ROHM	Dnnp x2	$V_{CE0}=50$ В; $I_{CM}=100$ мА; $P_D=300$ мВт; $h_{21} > 56$; 10 кОм/10 кОм	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1



SOT23-5
TSOT23-5



SOT553

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
A10	UMA10N	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $R_2/R_1 = 10$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A10	UMA9N	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A11	EMA11	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $4,7\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A11	FMA11A	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $4,7\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
A11	UMA11N	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $4,7\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A2	1SS309	TOSH	di x4	$V_F < 80\text{ В}; I_F < 300\text{ мА}; V_F(I_F = 100\text{ мА}) < 1,2\text{ В};$ $I_R < 0,5\text{ мА}; I_{RR} < 4\text{ нс}$	SOT23-5	A1•K•A2•A3•A4
A2	EMA2	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ $47\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A2	FMA2A	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ $47\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
A2	UMA2N	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ $47\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A2G	OP179GRT	AD	OA	R-R; $V_{DD} = 5...12\text{ В}; f_{BD} = 5\text{ МГц}; I_S = 3,5\text{ мА};$ $V_{OS} < \pm 5\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT•V+•+IN•-IN•V-
A3	EMA3	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ $R_1, 4,7\text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A3	FMA3A	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ $R_1, 4,7\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
A3	UMA3N	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ $R_1, 4,7\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A36	OPA336NA	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 2,3...5,5\text{ В}; I_S = 42\text{ мкА}; V_{OS} < \pm 125\text{ мкВ}$	SOT23-5	OUT•V-•+IN•-IN•V+
A38	OPA338N	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 2,5...5,5\text{ В}; f_{BD} = 12,5\text{ МГц}; I_S = 2\text{ мА};$ $V_{OS} < \pm 3,5\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT•V-•+IN•-IN•V+
A3A	AD8519ART	AD	OA	$f_{BD} = 8\text{ МГц}; P_D = 12\text{ мВт}; V_{DD} = 2,7...12\text{ В}$	SOT23-5	OUT•A•V-•+IN•A•-IN•A•V+
A3B	AD8519AKS	AD	OA	$f_{BD} = 8\text{ МГц}; P_D = 12\text{ мВт}; V_{DD} = 2,7...12\text{ В}$	SOT353, SC88A	OUT•A•V-•+IN•A•-IN•A•V+
A4	EMA4	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ $R_1, 10\text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A4	FMA4A	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ $R_1, 10\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
A4	UMA4N	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ $R_1, 10\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A40	OPA340NA	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 2,7...5,5\text{ В}; f_{BD} = 5,5\text{ МГц}; I_S = 1,1\text{ мА};$ $V_{OS} < \pm 0,5\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT•V-•+IN•-IN•V+
A41	OPA364I	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 1,8...5,5\text{ В}; f_{BD} = 7\text{ МГц}; I_S = 1,4\text{ мА};$ $V_{OS} < 0,9\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT•V-•+IN•-IN•V+
A44	OPA244NA	TI	OA	$V_{DD} = 2,2...3,6/\pm 1,1...18\text{ В}; I_S = 70\text{ мкА};$ $V_{OS} < \pm 2\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT•V-•+IN•-IN•V+
A47	OPA347NA	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 2,3...5,5\text{ В}; f_{BD} = 350\text{ кГц}; I_S = 43\text{ мкА};$ $V_{OS} < 7\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT•V-•+IN•-IN•V+
A48	OPA348AI	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 2,1...5,5\text{ В}; f_{BD} = 1\text{ МГц}; I_S = 75\text{ мкА};$ $V_{OS} < 6\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT•V-•+IN•-IN•V+
A4A	AD8541ART	AD	OA	$f_{BD} = 1\text{ МГц}; P_D = 0,3\text{ мВт}; V_{DD} = 2,7...5,5\text{ В}$	SOT23-5	OUT•A•V-•+IN•A•-IN•A•V+
A4B	AD8541AKS	AD	OA	$f_{BD} = 1\text{ МГц}; P_D = 0,3\text{ мВт}; V_{DD} = 2,7...5,5\text{ В}$	SOT353, SC88A	OUT•A•V-•+IN•A•-IN•A•V+
A5	EMA5	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ $R_2/R_1 = 21$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A5	FMA5A	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ $R_2/R_1 = 21$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
A5	UMA5N	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ $R_2/R_1 = 21$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A6	FMA6A	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ $R_1, 47\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1

SOT553

SOT353
SC88ASOT23-5
TSOT23-5

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
A6	UM6N	ROHM	Drnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>68;$ $R_1/47\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A6A	AD8614ART	AD	OA	$f_{80}=5.5\text{ МГц}; P_D=20\text{ мВт}; V_{DD}=5...18\text{ В}$	SOT23-5	OUT A•V••IN•-IN•V+
A7	EMA7	ROHM	Drnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>68;$ $R_2/R_1=2.1$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A7	FMA7A	ROHM	Drnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>68;$ $R_2/R_1=2.1$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
A7	UMA7N	ROHM	Drnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>68;$ $R_2/R_1=2.1$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A7A	AD8531ART	AD	OA	$f_{80}=3\text{ МГц}; P_D=6\text{ мВт}; V_{DD}=2.7...6\text{ В}$	SOT23-5	OUT A•V••IN A•-IN A•V+
A7B	AD8531AKS	AD	OA	$f_{80}=3\text{ МГц}; P_D=6\text{ мВт}; V_{DD}=2.7...6\text{ В}$	SOT353, SC88A	OUT A•V••IN A•-IN A•V+
A8	EMA8	ROHM	Drnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>68;$ $R_2/R_1=4.7$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
A8	FMA8A	ROHM	Drnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>68;$ $R_2/R_1=4.7$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
A8	UM6N	ROHM	Drnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>68;$ $R_2/R_1=4.7$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
AAA	AD8601ART	AD	OA	$f_{80}=8\text{ МГц}; P_D=6\text{ мВт}; V_{DD}=2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-5	OUT A•V••IN A•-IN•V+
AAA	MAX4450EXX	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=4.5...11\pm 2.25...5.5\text{ В}; f_{80}=210\text{ МГц};$ $V_{OS}<25\text{ мВ}$	SOT353, SC88A	OUT•VEE•IN•IN•VCC
AAAA	MAX4501UK	MAX	asw	SPST; $R_{ON}<350\text{ Ом}; V_{DD}=2...12\text{ В}$	SOT23-5	COM•NO•GND•IN•V+
AAAB	MAX4502UK	MAX	asw	SPST; $R_{ON}<350\text{ Ом}; V_{DD}=2...12\text{ В}$	SOT23-5	COM•NC•GND•IN•V+
AAAG	MAX4516CUK	MAX	asw	SPST; $R_{ON}<25\text{ Ом}; V_{DD}=2...16\text{ В}$	SOT23-5	COM•NO•V•IN•V+
AAAH	MAX4517CUK	MAX	asw	SPST; $R_{ON}<25\text{ Ом}; V_{DD}=2...16\text{ В}$	SOT23-5	COM•NC•V•IN•V+
AAB	MAX4490AXX	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.7...5.5\pm 1.35...2.75\text{ В}; f_{80}=10\text{ МГц};$ $V_{OS}<16\text{ мВ}$	SOT353, SC88A	IN•VSS•IN•OUT•VDD
AABK	MAX2631EUK	MAX	amp	$V_{CC}=2.7...5.5\text{ В}; f_p<900\text{ МГц}; I_{CC}=6.6\text{ мА}$	SOT23-5	SHDN•GND•OUT•VCC•IN
AABL	MAX2632EUK	MAX	amp	$V_{CC}=2.7...5.5\text{ В}; f_p<900\text{ МГц}; I_{CC}=6.6\text{ мА}$	SOT23-5	BIAS•GND•OUT•VCC•IN
AABZ	MAX4200EUK	MAX	buf	$V_{DD}=2.7\text{ В}; f_{80}=780\text{ МГц}; \text{Gain}=0.96; V_{OS}<15\text{ мВ}$	SOT23-5	n. c. •VEE•IN•VCC•OUT
AAC	MAX9075EXX	MAX	cmp	R-R; $V_{OS}<28\text{ мВ}; V_{CC}=2.1...5.5\text{ В}; I_{CC}<6.6\text{ мкА}$	SOT353, SC88A	OUT•GND•IN•IN•VCC
AAD	AD8601DRT	AD	OA	$f_{80}=8\text{ МГц}; P_D=6\text{ мВт}; V_{DD}=2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-5	OUT A•V••IN A•-IN•V+
AAD	MAX4291EXX	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=1.8...5.5\pm 0.9...2.75\text{ В}; f_{80}=500\text{ кГц};$ $V_{OS}<2.5\text{ мВ}$	SOT353, SC88A	IN•VVEE•IN•OUT•VCC
AAE	MAX4501EXX	MAX	asw	SPST; $R_{ON}<350\text{ Ом}; V_{DD}=2...12\text{ В}$	SOT353, SC88A	COM•NO•GND•IN•V+
AAF	MAX4502EXX	MAX	asw	SPST; $R_{ON}<350\text{ Ом}; V_{DD}=2...12\text{ В}$	SOT353, SC88A	COM•NC•GND•IN•V+
AAFx	SA56606-20	PHIL	misc	$V_{TR}=2.0\text{ В}; V_{DD}=1...12\text{ В}; I_{OUT}<50\text{ мА}; x = \text{код даты}$	SOT23-5	VOUT•VDD•VSS•n. c. •n. c.
AAG	MAX4400AXX	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.5...5.5\text{ В}; f_{80}=800\text{ кГц}; V_{OS}<5.5\text{ мВ}$	SOT353, SC88A	IN•VSS•IN•OUT•VDD
AAGx	SA56606-27	PHIL	misc	$V_{TR}=2.7\text{ В}; V_{DD}=1...12\text{ В}; I_{OUT}<50\text{ мА}; x = \text{код даты}$	SOT23-5	VOUT•VDD•VSS•n. c. •n. c.
AAH	MAX4594EXX	MAX	asw	SPST; $R_{ON}<12\text{ Ом}; V_{DD}=2.0...5.5\text{ В}$	SOT353, SC88A	COM•NO•GND•IN•V+
AAHx	SA56606-28	PHIL	misc	$V_{TR}=2.8\text{ В}; V_{DD}=1...12\text{ В}; I_{OUT}<50\text{ мА}; x = \text{код даты}$	SOT23-5	VOUT•VDD•VSS•n. c. •n. c.
AAI	MAX4595EXX	MAX	asw	SPST; $R_{ON}<12\text{ Ом}; V_{DD}=2.0...5.5\text{ В}$	SOT353, SC88A	COM•NC•GND•IN•V+
AAJ	MAX4596EXX	MAX	asw	SPST; $R_{ON}<12\text{ Ом}; V_{DD}=2.0...5.5\text{ В}$	SOT353, SC88A	IN•COM•GND•NO•V+
AAJx	SA56606-29	PHIL	misc	$V_{TR}=2.9\text{ В}; V_{DD}=1...12\text{ В}; I_{OUT}<50\text{ мА}; x = \text{код даты}$	SOT23-5	VOUT•VDD•VSS•n. c. •n. c.
AAK	MAX4597EXX	MAX	asw	SPST; $R_{ON}<12\text{ Ом}; V_{DD}=2.0...5.5\text{ В}$	SOT353, SC88A	IN•COM•GND•NC•V+
AAKx	SA56606-30	PHIL	misc	$V_{TR}=3.0\text{ В}; V_{DD}=1...12\text{ В}; I_{OUT}<50\text{ мА}; x = \text{код даты}$	SOT23-5	VOUT•VDD•VSS•n. c. •n. c.
AAIx	SA56606-31	PHIL	misc	$V_{TR}=3.1\text{ В}; V_{DD}=1...12\text{ В}; I_{OUT}<50\text{ мА}; x = \text{код даты}$	SOT23-5	VOUT•VDD•VSS•n. c. •n. c.



SOT23-5
TSOT23-5



SOT553

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
AAMx	SA56606-42	PHIL	mrc	$V_{TR} = 4.2\text{ В}; V_{DD} = 1...12\text{ В}; I_{OUT} < 50\text{ мА};$ x — КОД ДАТЫ	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
AANx	SA56606-43	PHIL	mrc	$V_{TR} = 4.3\text{ В}; V_{DD} = 1...12\text{ В}; I_{OUT} < 50\text{ мА};$ x — КОД ДАТЫ	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
AAPx	SA56606-44	PHIL	mrc	$V_{TR} = 4.4\text{ В}; V_{DD} = 1...12\text{ В}; I_{OUT} < 50\text{ мА};$ x — КОД ДАТЫ	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
AARx	SA56606-45	PHIL	mrc	$V_{TR} = 4.5\text{ В}; V_{DD} = 1...12\text{ В}; I_{OUT} < 50\text{ мА};$ x — КОД ДАТЫ	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
AASx	SA56606-46	PHIL	mrc	$V_{TR} = 4.6\text{ В}; V_{DD} = 1...12\text{ В}; I_{OUT} < 50\text{ мА};$ x — КОД ДАТЫ	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
AATx	SA56606-47	PHIL	mrc	$V_{TR} = 4.7\text{ В}; V_{DD} = 1...12\text{ В}; I_{OUT} < 50\text{ мА};$ x — КОД ДАТЫ	SOT23-5	VOUT • VDD • VSS • n. c. • n. c.
ABAA	MAX4201EUK	MAX	buf	$V_{DD} = \pm 5\text{ В}; f_{BD} = 780\text{ МГц}; \text{Gain} = 0.5; R_T = 50\text{ Ом}; V_{OS} < 15\text{ мВ}$	SOT23-5	n. c. • VEE • IN • VCC • OUT
ABAB	MAX4202EUK	MAX	buf	$V_{DD} = \pm 5\text{ В}; f_{BD} = 780\text{ МГц}; \text{Gain} = 0.5; R_T = 75\text{ Ом}; V_{OS} < 15\text{ мВ}$	SOT23-5	n. c. • VEE • IN • VCC • OUT
ABAF	MAX4212EUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 3.3...10/\pm 1.65...5\text{ В}; f_{BD} = 300\text{ МГц}; V_{OS} < 12\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABAH	MAX4214EUK	MAX	buf	R-R; $V_{DD} = 3.15...11/\pm 1.575...5\text{ В}; f_{BD} = 230\text{ МГц}; \text{Gain} = 2; V_{OS} < 15\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABAJ	MAX4330EUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.3...6.5/\pm 1.15...3.25\text{ В}; f_{BD} = 3\text{ МГц}; V_{OS} < 1.5\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABAK	MAX6305UK00D1	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RST IN1 • RST IN2 • VCC
ABAL	MAX6305UK00D2	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RST IN1 • RST IN2 • VCC
ABAM	MAX6305UK00D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RST IN1 • RST IN2 • VCC
ABBB	MAX6306UK47D2	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABBG	MAX6306UK46D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABBO	MAX6306UK44D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABDO	MAX6306UK31D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABDP	MAX6306UK31D4	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABDQ	MAX6306UK30D1	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABDS	MAX6306UK30D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABDW	MAX6306UK29D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABEA	MAX6306UK28D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABEK	MAX6306UK25D1	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABEM	MAX6306UK25D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABFG	MAX6307UK46D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RST IN • OVRST IN • VCC
ABFJ	MAX6307UK45D2	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RST IN • OVRST IN • VCC
ABFO	MAX6307UK44D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RST IN • OVRST IN • VCC
ABG	MAX9031AXK	MAX	cmp	R-R; $V_{OS} < \pm 5\text{ мВ}; V_{DD} = 2.5...5.5\text{ В}; I_{DD} < 55\text{ мкА}$	SOT353, SC88A	IN+ • VSS • IN- • OUT • VDD
ABGY	MAX6307UK35D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RST IN • OVRST IN • VCC
ABH	MAX4412EXK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}; f_{BD} = 500\text{ МГц}; V_{OS} < 9\text{ мВ}$	SOT353, SC88A	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABI	MAX4452EXK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.7...5.25\text{ В}; f_{BD} = 200\text{ МГц}; V_{OS} < 12\text{ мВ}$	SOT353, SC88A	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ABIO	MAX6308UK00D1	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RST IN1 • RST IN2 • VCC
ABIQ	MAX6308UK00D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RST IN1 • RST IN2 • VCC

SOT553

SOT353
SC88ASOT23-5
TSOT23-5

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4+5
ABJ	MAX4352EXK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.7...5.25$ В; $f_{BD} = 80$ МГц; $V_{OS} < 12$ мВ	SOT353, SC88A	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ABJK	MAX6309UK46D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABJL	MAX6309UK46D4	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABJS	MAX6309UK44D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABK	MAX985EXK	MAX	cmp	R-R; $V_{OS} < 7$ мВ; $V_{CC} = 2.5...5.5$ В; $I_{CC} < 24$ мкА	SOT353, SC88A	OUT • VCC • IN+ • IN • VEE
ABKA	MAX6309UK42D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABL	MAX986EXK	MAX	cmp	R-R; $V_{OS} < 7$ мВ; $V_{CC} = 2.5...5.5$ В; $I_{CC} < 24$ мкА	SOT353, SC88A	OUT • VCC • IN+ • IN • VEE
ABLM	MAX6309UK32D1	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABLS	MAX6309UK31D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABM	MAX987EXK	MAX	cmp	R-R; $V_{OS} < 7$ мВ; $V_{CC} = 2.5...5.5$ В; $I_{CC} < 96$ мкА	SOT353, SC88A	OUT • VCC • IN+ • IN • VEE
ABMA	MAX6309UK29D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABN	MAX988EXK	MAX	cmp	R-R; $V_{OS} < 7$ мВ; $V_{CC} = 2.5...5.5$ В; $I_{CC} < 96$ мкА	SOT353, SC88A	OUT • VCC • IN+ • IN • VEE
ABNK	MAX6310UK46D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN • OVRST IN • VCC
ABO	MAX6605MXK	MAX	ats	$T_{AMB} = -55...125$ °C; $V_{CC} = 2.7...5.5$ В; $I_{CC} < 10$ мА	SOT353, SC88A	VCC • A • OUT • B • GND
ABOH	MAX6310UK40D2	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN • OVRST IN • VCC
ABP	MAX9021AXK	MAX	cmp	R-R; $V_{OS} < 8$ мВ; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; $I_{DD} < 5$ мкА	SOT353, SC88A	IN+ • VSS • IN • OUT • VDD
ABQ	MAX4484AXK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.7...5.5$ В; $f_{BD} = 7$ МГц; $V_{OS} < 9$ мВ	SOT353, SC88A	IN+ • VSS • IN • OUT • VDD
ABQU	MAX6311UK00D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN1 • RST IN2 • VCC
ABR	MAX4493AXK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.25...5.5$ В; $f_{BD} = 5$ МГц; $V_{OS} < 10$ мВ	SOT353, SC88A	IN+ • VEE • IN • OUT • VCC
ABRO	MAX6312UK46D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABRP	MAX6312UK46D4	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABRW	MAX6312UK44D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABS	MAX4470EXK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 1.8...5.5$ В; $f_{BD} = 9$ МГц; $I_{CC} < 1.2$ мкА; $V_{OS} < 7$ мВ	SOT353, SC88A	IN+ • VSS • IN • OUT • VDD
ABSA	MAX6312UK43D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABT	MAX4464EXK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 1.8...5.5$ В; $f_{BD} = 40$ МГц; $I_{CC} < 1.2$ мкА; $V_{OS} < 7$ мВ	SOT353, SC88A	IN+ • VSS • IN • OUT • VDD
ABU	MAX4480AXK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; $I_{CC} < 100$ мкА; $V_{OS} < 5.5$ мВ	SOT353, SC88A	IN+ • VSS • IN • OUT • VDD
ABUE	MAX6312UK29D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ABV	MAX3370EXK	MAX	levtrans	RS-232; $V_{CC} = 2.5...5.5$ В; $f_{BD} = 2$ Мбит/с; $I_{CC} < 100$ мкА	SOT353, SC88A	VI • GND • I/O VLT • I/O VCC • VCC
ABVO	MAX6313UK46D3	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5...5$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES • GND • RST IN • OVRST IN • VCC
ABW	MAX9117EXK	MAX	cmp+vref	$V_{OS} < 10$ мВ; $V_{CC} = 1.8...5.5$ В; $V_{REF} = 1.252$ В; $I_{CC} < 1.6$ мкА	SOT353, SC88A	OUT • VEE • IN+ • REF • VCC
ABX	MAX9118EXK	MAX	cmp+vref	$V_{OS} < 10$ мВ; $V_{CC} = 1.8...5.5$ В; $V_{REF} = 1.252$ В; $I_{CC} < 1.6$ мкА	SOT353, SC88A	OUT • VEE • IN+ • REF • VCC
ABY	MAX9119EXK	MAX	cmp	$V_{OS} < 10$ мВ; $V_{CC} = 1.8...5.5$ В; $I_{CC} < 0.8$ мкА	SOT353, SC88A	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ABYW	MAX477EUK	MAX	OA	$V_{DD} = 15$ В; $f_{BD} = 300$ МГц; $V_{OS} < 5$ мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN • VCC
ABYX	MAX4178EUK	MAX	buf	$V_{DD} = 5$ В; $f_{BD} = 330$ МГц; $V_{OS} < 3$ мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN • GND • VCC
ABYY	MAX4278EUK	MAX	buf	$V_{DD} = 5$ В; $f_{BD} = 310$ МГц; $V_{OS} < 3$ мВ	SOT23-5	OUT • VEE • IN • GND • VCC
ABYZ	MAX985EUK	MAX	cmp	R-R; $V_{OS} < 7$ мВ; $V_{CC} = 2.5...5.5$ В; $I_{CC} < 24$ мкА	SOT23-5	OUT • VCC • IN+ • IN • VEE



SOT23-5 **SOT353**
TSOT23-5 **SC88A**



SOT553

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4+5
ABZ	MAX9120EXK	MAX	cmp	$V_{OS} < 10 \text{ мВ}; V_{CC} = 1.8...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 0.8 \text{ мкА}$	SOT353, SC88A	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ABZA	MAX986EUK	MAX	cmp	R-R; $V_{OS} \leq \pm 7 \text{ мВ}; V_{CC} = 2.5...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 24 \text{ мкА}$	SOT23-5	OUT•VCC•IN+•IN-•VEE
ABZB	MAX987EUK	MAX	cmp	R-R; $V_{OS} \leq \pm 7 \text{ мВ}; V_{CC} = 2.5...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 96 \text{ мкА}$	SOT23-5	OUT•VCC•IN+•IN-•VEE
ABZC	MAX988EUK	MAX	cmp	R-R; $V_{OS} \leq \pm 7 \text{ мВ}; V_{CC} = 2.5...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 96 \text{ мкА}$	SOT23-5	OUT•VCC•IN+•IN-•VEE
ABZD	MAX1615EUK	MAX	reg	$V_{IN} = 4...28 \text{ В}; V_{OUT} = 3.3/5 \text{ В}; I_{OUT} = 30 \text{ мА}$	SOT23-5	IN•GND•OUT•5/3 (FB)•SHDN
ABZE	MAX1616EUK	MAX	reg	$V_{IN} = 4...28 \text{ В}; V_{OUT} = 1.24...28 \text{ В}; I_{OUT} = 30 \text{ мА}$	SOT23-5	IN•GND•OUT•5/3 (FB)•SHDN
ABZF	MAX6501UKP035	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = +35^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ABZG	MAX6502UKP035	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = +35^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ABZH	MAX8873TUK	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5 \text{ В}; V_{OUT} = 3.15 \text{ В}; I_{OUT} = 120 \text{ мА}$	SOT23-5	IN•GND•SHDN•SET•OUT
ABZJ	MAX8873SUK	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5 \text{ В}; V_{OUT} = 2.88 \text{ В}; I_{OUT} = 120 \text{ мА}$	SOT23-5	IN•GND•SHDN•SET•OUT
ABZJ	MAX8874TUK	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5 \text{ В}; V_{OUT} = 3.15 \text{ В}; I_{OUT} = 120 \text{ мА}$	SOT23-5	IN•GND•SHDN•SET•OUT
ABZK	MAX8874SUK	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5 \text{ В}; V_{OUT} = 2.88 \text{ В}; I_{OUT} = 120 \text{ мА}$	SOT23-5	IN•GND•SHDN•SET•OUT
ABZL	MAX8873RUK	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5 \text{ В}; V_{OUT} = 2.8 \text{ В}; I_{OUT} = 120 \text{ мА}$	SOT23-5	IN•GND•SHDN•SET•OUT
ABZM	MAX8874RUK	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5 \text{ В}; V_{OUT} = 2.8 \text{ В}; I_{OUT} = 120 \text{ мА}$	SOT23-5	IN•GND•SHDN•SET•OUT
ABZP	MAX4012EUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 3.3...10/1.65...5 \text{ В}; f_{BD} = 200 \text{ МГц}; V_{OS} < 20 \text{ мВ}$	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ABZQ	MAX4014EUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 3.15...11/1.575...5.5 \text{ В}; f_{BD} = 200 \text{ МГц}; V_{OS} < 20 \text{ мВ}$	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ABZR	MAX6501UKP045	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = +45^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ABZS	MAX6501UKP065	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = +65^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ABZT	MAX6501UKP095	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = +95^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ABZU	MAX6502UKP045	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = +45^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ABZV	MAX6502UKP065	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = +65^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ABZW	MAX6502UKP095	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = +95^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ABZX	MAX6503UKP005	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = +5^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TUNDER
ABZY	MAX6504UKP005	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = +5^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TUNDER
ACA	MAX5460EXK	MAX	Dpot	32 позиции; $100 \text{ кОм}; V_{DD} = 2.7...5.5 \text{ В}$	SOT353, SC88A	VDD•GND•U/D•CS•H
ACAB	MAX999EUK	MAX	cmp	R-R; $V_{OS} \leq \pm 4.5 \text{ мВ}; V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 5 \text{ мА}$	SOT23-5	Q•GND•IN+•IN-•VCC
ACAG	MAX6501UKP115	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = +115^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ACAM	MAX6503UKP015	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = +15^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TUNDER
ACAN	MAX6503UKN005	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = -5^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TUNDER
ACAP	MAX6503UKN025	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = -25^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TUNDER
ACAQ	MAX6503UKN035	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = -35^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TUNDER
ACAT	MAX6504UKN005	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = -5^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TUNDER
ACAV	MAX6504UKN025	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = -25^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TUNDER
ACAW	MAX6504UKN035	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = -35^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TUNDER
ACAX	MAX6504UKN045	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5 \text{ В}; T_{TH} = -45^\circ \text{C}; I_{CC} < 85 \text{ мкА}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TUNDER
ACAY	MAX8867UK25	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5 \text{ В}; V_{OUT} = 2.5 \text{ В}; I_{OUT} = 150 \text{ мА}$	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ACAZ	MAX8867UK28	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5 \text{ В}; V_{OUT} = 2.8 \text{ В}; I_{OUT} = 150 \text{ мА}$	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ACB	MAX5463EXK	MAX	Dpot	32 позиции; $50 \text{ кОм}; V_{DD} = 2.7...5.5 \text{ В}$	SOT353, SC88A	VDD•GND•U/D•CS•H
ACBA	MAX8867UK29	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5 \text{ В}; V_{OUT} = 2.84 \text{ В}; I_{OUT} = 150 \text{ мА}$	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ACBB	MAX8867UK30	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5 \text{ В}; V_{OUT} = 3.0 \text{ В}; I_{OUT} = 150 \text{ мА}$	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP

SOT553

SOT353
SC88ASOT23-5
TSOT23-5

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ACBC	MAX8867UK32	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...6.5$ В; $V_{OUT}=3.15$ В; $I_{OUT}=150$ мА	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ACBD	MAX8867UK33	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...6.5$ В; $V_{OUT}=3.3$ В; $I_{OUT}=150$ мА	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ACBE	MAX8867UK50	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...6.5$ В; $V_{OUT}=5.0$ В; $I_{OUT}=150$ мА	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ACBF	MAX8868UK25	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...6.5$ В; $V_{OUT}=2.5$ В; $I_{OUT}=150$ мА	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ACBG	MAX8868UK28	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...6.5$ В; $V_{OUT}=2.8$ В; $I_{OUT}=150$ мА	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ACBH	MAX8868UK29	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...6.5$ В; $V_{OUT}=2.84$ В; $I_{OUT}=150$ мА	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ACBI	MAX8868UK30	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...6.5$ В; $V_{OUT}=3.0$ В; $I_{OUT}=150$ мА	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ACBJ	MAX8868UK32	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...6.5$ В; $V_{OUT}=3.15$ В; $I_{OUT}=150$ мА	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ACBK	MAX8868UK33	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...6.5$ В; $V_{OUT}=3.3$ В; $I_{OUT}=150$ мА	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ACBL	MAX8868UK50	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...6.5$ В; $V_{OUT}=5.0$ В; $I_{OUT}=150$ мА	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ACC	MAX9140EXK	MAX	cmp	$V_{OS}<4.5$ мВ; $V_{CC}=2.7...5.5$ В; $I_{CC}<300$ мкА	SOT353, SC88A	OUT•GND•IN+•IN-•VCC
ACCO	MAX4104EUK	MAX	OA	$V_{DD}=±3.5...±5.5$ В; $f_{DB}=625$ МГц; $V_{OS}<8$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACCP	MAX4105EUK	MAX	OA	$V_{DD}=±3.5...±5.5$ В; $f_{DB}=410$ МГц; $V_{OS}<8$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACCO	MAX4304EUK	MAX	OA	$V_{DD}=±3.5...±5.5$ В; $f_{DB}=730$ МГц; $V_{OS}<8$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACCR	MAX4305EUK	MAX	OA	$V_{DD}=±3.5...±5.5$ В; $f_{DB}=340$ МГц; $V_{OS}<8$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACCS	MAX4240EUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=1.8...5.5±0.9...±2.75$ В; $I_{CC}<18$ мкА; $V_{OS}<1.4$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACCC	MAX8867UK36	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...6.5$ В; $V_{OUT}=3.6$ В; $I_{OUT}=150$ мА	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ACDA	MAX8868UK36	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...6.5$ В; $V_{OUT}=3.6$ В; $I_{OUT}=150$ мА	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ACDD	MAX6316LUK46C	MAX	mrc	$V_{TR}=4.63$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{CC}<20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•WDI•VCC
ACDE	MAX6316LUK29C	MAX	mrc	$V_{TR}=2.93$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{CC}<20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•WDI•VCC
ACDF	MAX6316MUK46C	MAX	mrc	$V_{TR}=4.63$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{CC}<20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•WDI•VCC
ACDG	MAX6316MUK29C	MAX	mrc	$V_{TR}=2.93$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{CC}<20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•WDI•VCC
ACDH	MAX6318LUK46C	MAX	mrc	$V_{TR}=4.63$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{CC}<20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•WDI•VCC
ACDI	MAX6318LUK29C	MAX	mrc	$V_{TR}=2.93$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{CC}<20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•WDI•VCC
ACDJ	MAX6318MHUK46C	MAX	mrc	$V_{TR}=4.63$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{CC}<20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•WDI•VCC
ACDK	MAX6319LUK46C	MAX	mrc	$V_{TR}=4.63$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{CC}<20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•MR•VCC
ACDL	MAX6319LUK29C	MAX	mrc	$V_{TR}=2.93$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{CC}<20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•MR•VCC
ACDM	MAX6319MHUK46C	MAX	mrc	$V_{TR}=4.63$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{CC}<20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•MR•VCC
ACDN	MAX6320PUK46C	MAX	mrc	$V_{TR}=4.63$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{CC}<20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•WDI•VCC
ACDO	MAX6320PUK29C	MAX	mrc	$V_{TR}=2.93$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{CC}<20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•WDI•VCC
ACDP	MAX6501UKP085	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $T_{TH}=+85$ °C; $I_{CC}<85$ мкА	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ACDQ	MAX6317HUK46C	MAX	mrc	$V_{TR}=4.63$ В; $V_{DD}=1...5.5$ В; $I_{CC}<20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•WDI•VCC
ACDR	MAX4281EUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.5...5.5$ В; Gain=1; $I_S<530$ мкА; $V_{OS}<2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACDS	MAX4174ABUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.5...5.5$ В; Gain=1.25; $I_S<530$ мкА; $V_{OS}<2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACDT	MAX4174ACUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.5...5.5$ В; Gain=1.5; $I_S<530$ мкА; $V_{OS}<2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACDU	MAX4174ADUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.5...5.5$ В; Gain=2; $I_S<530$ мкА; $V_{OS}<32.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACDV	MAX4174AEUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.5...5.5$ В; Gain=2.25; $I_S<530$ мкА; $V_{OS}<2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACDW	MAX4174AFUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.5...5.5$ В; Gain=2.5; $I_S<530$ мкА; $V_{OS}<2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACDX	MAX4174AGUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.5...5.5$ В; Gain=3; $I_S<530$ мкА; $V_{OS}<2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACDY	MAX4174AHUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.5...5.5$ В; Gain=3.5; $I_S<530$ мкА; $V_{OS}<2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACDZ	MAX4174AJUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.5...5.5$ В; Gain=4; $I_S<530$ мкА; $V_{OS}<2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEA	MAX4174AKUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.5...5.5$ В; Gain=5; $I_S<530$ мкА; $V_{OS}<2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC



SOT23-5 **SOT353**
TSOT23-5 **SC88A**



SOT553

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ACEB	MAX4174ALLUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 6; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEC	MAX4174AMUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 7; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACED	MAX4174ANUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 9; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEE	MAX4174AOUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 10; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEF	MAX4174BAUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 11; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEG	MAX4174BBUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 13.5; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEH	MAX4174BCUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 16; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEI	MAX4174BDUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 21; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEJ	MAX4174BEUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 25; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEK	MAX4174BFUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 26; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEL	MAX4174BGUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 31; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEM	MAX4174BHUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 41; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEN	MAX4174BJUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 50; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEO	MAX4174BKUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 51; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEP	MAX4174BLUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 61; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEQ	MAX4174BMUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 80; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACER	MAX4174BNUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 100; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACES	MAX4174CAUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 101; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACET	MAX4175ABUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 1.25; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEU	MAX4175ACUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 1.5; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEV	MAX4175ADUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 2; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 32.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEW	MAX4175AEUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 2.25; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEX	MAX4175AFUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 2.5; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEY	MAX4175AGUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 3; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACEZ	MAX4175AHUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 3.5; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACF	MAX4350EXK	MAX	OA	R-R; $V_{DS} = +4.5...+5.5$ В; $f_{BD} = 210$ МГц; $V_{OS1} < 26$ мВ	SOT353, SC88A	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACFA	MAX4175AJUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 4; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACFB	MAX4175AKUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 5; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ACFC	MAX4175ALLUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 6; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS1} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC

SOT553

SOT353
SC88ASOT23-5
TSOT23-5

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ACFD	MAX4175AMUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 7; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFE	MAX4175ANUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 9; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFF	MAX4175AOUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 10; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFG	MAX4175BAUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 11; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFH	MAX4175BBUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 13.5; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFI	MAX4175BCUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 16; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFJ	MAX4175BDUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 21; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFK	MAX4175BEUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 25; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFL	MAX4175BFUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 26; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFM	MAX4175BGUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 31; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFN	MAX4175BHUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 41; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFO	MAX4175BJUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 50; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFP	MAX4175BKUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 51; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFQ	MAX4175BLUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 61; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFR	MAX4175BMUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 80; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFS	MAX4175BNUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 100; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFT	MAX4175CAUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 101; $I_S < 530$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACFU	MAX6501UKP105	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7 \dots 5.5$ В; $T_{RH} = +105$ °C; $I_{CC} < 85$ мкА	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ACFV	MAX6501UKP075	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7 \dots 5.5$ В; $T_{RH} = +75$ °C; $I_{CC} < 85$ мкА	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ACFW	MAX6501UKP055	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7 \dots 5.5$ В; $T_{RH} = +55$ °C; $I_{CC} < 85$ мкА	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ACFX	MAX6503UKN015	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7 \dots 5.5$ В; $T_{RH} = -15$ °C; $I_{CC} < 85$ мкА	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TUNDR
ACFY	MAX6502UKP115	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7 \dots 5.5$ В; $T_{RH} = +115$ °C; $I_{CC} < 85$ мкА	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ACFZ	MAX6502UKP105	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7 \dots 5.5$ В; $T_{RH} = +105$ °C; $I_{CC} < 85$ мкА	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ACG	MAX4465EXK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.4 \dots 5.5$ В; $I_{BO} = 200$ мА; $I_{CC} < 60$ мкА; $V_{OS} < 5$ мВ	SOT353, SC88A	IN+•GND•IN•OUT•VCC
ACGA	MAX6502UKP085	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7 \dots 5.5$ В; $T_{RH} = +85$ °C; $I_{CC} < 85$ мкА	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ACGB	MAX6502UKP075	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7 \dots 5.5$ В; $T_{RH} = +75$ °C; $I_{CC} < 85$ мкА	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ACGC	MAX6502UKP055	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7 \dots 5.5$ В; $T_{RH} = +55$ °C; $I_{CC} < 85$ мкА	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
ACGD	MAX6504UKN015	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7 \dots 5.5$ В; $T_{RH} = -15$ °C; $I_{CC} < 85$ мкА	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TUNDR
ACGE	MAX4322EUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.4 \dots 6.5$; $\pm 1.2 \dots \pm 3.25$ В; $I_{BO} = 5$ мА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACGF	MAX4040EUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.4 \dots 5.5$; $\pm 1.2 \dots \pm 2.75$ В; $I_S < 20$ мкА; $V_{OS} < 2.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ACGJ	MAX6317HUK29C	MAX	mirc	$V_{TR} = 2.93$ В; $V_{DD} = 1 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•MIR•WDI•VCC
ACGK	MAX6321HPUK29	MAX	mirc	$V_{TR} = 2.93$ В; $V_{DD} = 1 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•WDI•VCC
ACGL	MAX6321HPUK46	MAX	mirc	$V_{TR} = 4.63$ В; $V_{DD} = 1 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•WDI•VCC
ACGM	MAX6322HPUK29	MAX	mirc	$V_{TR} = 2.93$ В; $V_{DD} = 1 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•MIR•VCC
ACGN	MAX6322HPUK46	MAX	mirc	$V_{TR} = 4.63$ В; $V_{DD} = 1 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•MIR•VCC



SOT23-5
TSOT23-5



SOT553

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ACGY	MAX987EUK	MAX	cmp	R-R; $V_{OS} < \pm 7$ мВ; $V_{CC} = 2.5...5.5$ В; $I_{CC} < 96$ мкА	SOT23-5	OUT•VCC•IN+•IN•VEE
ACH	MAX4466EJK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.4...5.5$ В; $f_{DB} = 200$ кГц; $I_{CC} < 60$ мкА; $V_{OS} < 5$ мВ	SOT353, SC88A	IN+•GND•IN•OUT•VCC
ACHF	MAX8867UK27	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5$ В; $V_{OUT} = 2.7$ В; $I_{OUT} = 150$ мА	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ADA	AD8517ART	AD	OA	$f_{DB} = 7$ МГц; $P_D = 6$ мВт; $V_{DD} = 1.8...6$ В	SOT23-5	OUT A•V+•IN A•IN A•V+
ADIP	MAX6319LHKU49	MAX	mic	$V_{FB} = 4.9$ В; $V_{DD} = 1...5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•MR•VCC
ADIQ	MAX917EUK	MAX	cmp+vref	$V_{OS} < 10$ мВ; $V_{CC} = 1.8...5.5$ В; $V_{REF} = 1.245$ В; $I_{CC} < 1.6$ мкА	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•REF•VCC
ADIR	MAX918EUK	MAX	cmp+vref	$V_{OS} < 10$ мВ; $V_{CC} = 1.8...5.5$ В; $V_{REF} = 1.245$ В; $I_{CC} < 1.6$ мкА	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•REF•VCC
ADIS	MAX919EUK	MAX	cmp	$V_{OS} < 10$ мВ; $V_{CC} = 1.8...5.5$ В; $I_{CC} < 0.8$ мкА	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADIT	MAX920EUK	MAX	cmp	$V_{OS} < 10$ мВ; $V_{CC} = 1.8...5.5$ В; $I_{CC} < 0.8$ мкА	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADIU	MAX4372EUK	MAX	CSA	$V_{DD} = 2.7...28$ В; Gain = 20; $I_{CC} < 1.9$ мА	SOT23-5	GND•OUT•VCC•RS+•RS-
ADV	MAX4372FEUK	MAX	CSA	$V_{DD} = 2.7...28$ В; Gain = 50; $I_{CC} < 1.9$ мА	SOT23-5	GND•OUT•VCC•RS+•RS-
ADW	MAX4372HEUK	MAX	CSA	$V_{DD} = 2.7...28$ В; Gain = 100; $I_{CC} < 1.9$ мА	SOT23-5	GND•OUT•VCC•RS+•RS-
ADIX	MAX1749EUK	MAX	vibdrv	$V_{IN} = 2.5...6.5$ В; $V_{OUT} = 1.25/1.25...6.5$ В; $I_{OUT} < 120$ мА	SOT23-5	ON•GND•IN•OUT•SET
ADIZ	MAX6503UKNO45	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5$ В; $T_{TH} = -45$ °C; $I_{CC} < 85$ мкА	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TUNDR
ADJA	MAX4076EUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 1; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJB	MAX4074ABUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 1.25; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJC	MAX4074ACUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 1.5; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJD	MAX4074ADUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 2; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJE	MAX4074AEUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 2.25; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJF	MAX4074AFUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 2.5; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJG	MAX4074AGUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 3; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJH	MAX4074AHUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 3.5; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJI	MAX4074AJUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 4; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJJ	MAX4074AKUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 5; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJK	MAX4074ALUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 6; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJL	MAX4074AMUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 7; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJM	MAX4074ANUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 9; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJN	MAX4074AOUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 10; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJO	MAX4074BAUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 11; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJP	MAX4074BBUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 13.5; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJQ	MAX4074BCUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 16; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJR	MAX4074BDUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 21; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJS	MAX4074BEUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; Gain = 25; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC

SOT553

SOT353
SC88ASOT23-5
TSOT23-5

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ADJT	MAX4074BFUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 26; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJU	MAX4074BGUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 31; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJV	MAX4074BHUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 41; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJW	MAX4074BJUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 50; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJX	MAX4074BKUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 51; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJY	MAX4074BLUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 61; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADJZ	MAX4074BMUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 80; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADKA	MAX4074BNUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 100; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADKB	MAX4074CAUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5$ В; Gain = 101; $I_S < 55$ мкА; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADKC	MAX6318LHUK49	MAX	mic	$V_{TR} = 4.9$ В; $V_{DD} = 1 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•WDI•VCC
ADKD	MAX8867UK40	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5 \dots 6.5$ В; $V_{OUT} = 4.0$ В; $I_{OUT} = 150$ мА	SOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ADKE	MAX6504UKP015	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7 \dots 5.5$ В; $T_{TH} = +15$ °С; $I_{CC} < 85$ мкА	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TUNDR
ADKF	MAX3180EUK	MAX	rec	RS-232; $V_{CC} = 3 \dots 5.5$ В; $f_{DR} = 1.5$ Мбит/с; $I_{CC} < 5$ мкА	SOT23-5	EN•GND•ROUT•RIN•VCC
ADKG	MAX3181EUK	MAX	rec	RS-232; $V_{CC} = 3 \dots 5.5$ В; $f_{DR} = 1.5$ Мбит/с; $I_{CC} < 5$ мкА	SOT23-5	INVALID•GND•ROUT•RIN•VCC
ADKH	MAX3182EUK	MAX	rec	RS-232; $V_{CC} = 3 \dots 5.5$ В; $f_{DR} = 1.5$ Мбит/с; $I_{CC} < 5$ мкА	SOT23-5	EN•GND•ROUT•RIN•VCC
ADKI	MAX3183EUK	MAX	rec	RS-232; $V_{CC} = 3 \dots 5.5$ В; $f_{DR} = 1.5$ Мбит/с; $I_{CC} < 5$ мкА	SOT23-5	INVALID•GND•ROUT•RIN•VCC
ADKJ	MAX6352LSUK	MAX	mic	$V_{TR1} = 4.63$ В; $V_{TR2} = 2.93$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-5	RST•GND•MR•VCC2•VCC1
ADKK	MAX6352SYUK	MAX	mic	$V_{TR1} = 2.93$ В; $V_{TR2} = 2.19$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-5	RST•GND•MR•VCC2•VCC1
ADKL	MAX6353LSUK	MAX	mic	$V_{TR1} = 4.63$ В; $V_{TR2} = 2.93$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-5	RST•GND•MR•VCC2•VCC1
ADKM	MAX6353SYUK	MAX	mic	$V_{TR1} = 2.93$ В; $V_{TR2} = 2.19$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-5	RST•GND•MR•VCC2•VCC1
ADKN	MAX6354LSUK	MAX	mic	$V_{TR1} = 4.63$ В; $V_{TR2} = 2.93$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-5	RST•GND•MR•VCC2•VCC1
ADKO	MAX6354SYUK	MAX	mic	$V_{TR1} = 2.93$ В; $V_{TR2} = 2.19$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-5	RST•GND•MR•VCC2•VCC1
ADKP	MAX4450EUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 4.5 \dots 11$ / $\pm 25 \dots \pm 5.5$ В; $f_{BD} = 210$ МГц; $V_{OS} < 26$ мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN•VCC
ADKQ	MAX4490AUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5$ / $\pm 1.35 \dots \pm 2.75$ В; $f_{BD} = 10$ МГц; $V_{OS} < 16$ мВ	SOT23-5	IN+•VSS•IN•OUT•VDD
ADKR	MAX6316LHUK46B	MAX	mic	$V_{TR} = 4.63$ В; $V_{DD} = 1 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•WDI•VCC
ADKS	MAX6306LHUK47D3	MAX	mic	$V_{TR} = 2.5 \dots 5.5$ В; $V_{DD} = 1 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 16$ мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•RST•IN•VCC
ADKT	MAX1734EUK33	MAX	dc/dc	$V_{IN} = 2.7 \dots 5.5$ В; $V_{OUT} = 3.3$ В; $I_{OUT} = 250$ мА	SOT23-5	IN•GND•SHDN•OUT (FB)•LX
ADKU	MAX1734EUK30	MAX	dc/dc	$V_{IN} = 2.7 \dots 5.5$ В; $V_{OUT} = 3$ В; $I_{OUT} = 250$ мА	SOT23-5	IN•GND•SHDN•OUT (FB)•LX
ADKV	MAX1734EUK25	MAX	dc/dc	$V_{IN} = 2.7 \dots 5.5$ В; $V_{OUT} = 2.5$ В; $I_{OUT} = 250$ мА	SOT23-5	IN•GND•SHDN•OUT (FB)•LX
ADKW	MAX1734EUK18	MAX	dc/dc	$V_{IN} = 2.7 \dots 5.5$ В; $V_{OUT} = 1.8$ В; $I_{OUT} = 250$ мА	SOT23-5	IN•GND•SHDN•OUT (FB)•LX
ADKX	MAX1734EUK15	MAX	dc/dc	$V_{IN} = 2.7 \dots 5.5$ В; $V_{OUT} = 1.5$ В; $I_{OUT} = 250$ мА	SOT23-5	IN•GND•SHDN•OUT (FB)•LX
ADKY	MAX1733EUK	MAX	dc/dc	$V_{IN} = 2.7 \dots 5.5$ В; $V_{OUT} = 1.25 \dots 2$ В; $I_{OUT} = 250$ мА	SOT23-5	IN•GND•SHDN•OUT (FB)•LX
ADLM	MAX6318LHUK26C	MAX	mic	$V_{TR} = 2.63$ В; $V_{DD} = 1 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•WDI•VCC
ADLO	MAX6318LHUK44C	MAX	mic	$V_{TR} = 4.39$ В; $V_{DD} = 1 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•WDI•VCC
ADLP	MAX6319LHUK26	MAX	mic	$V_{TR} = 2.63$ В; $V_{DD} = 1 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•MR•VCC



SOT23-5 **SOT353**
TSOT23-5 **SC88A**



SOT553

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ADLQ	MAX6319LHJK29	MAX	mic	$V_{FR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VCC
ADLR	MAX6319LHJK31	MAX	mic	$V_{FR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VCC
ADLS	MAX6319LHJK44	MAX	mic	$V_{FR} = 4.39\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VCC
ADLT	MAX6316LUK26C	MAX	mic	$V_{FR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADLU	MAX6316LUK31C	MAX	mic	$V_{FR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADLV	MAX6309UK27D1	MAX	mic	$V_{FR} = 2.5...5\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 16\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • RST IN • VCC
ADLX	MAX9075EUK	MAX	cmp	R-R; $V_{OS} \leq \pm 8\text{ мВ}; V_{CC} = 2.1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 6.6\text{ мкА}$	SOT23-5	OUT • GND • IN+ • IN- • VCC
ADMA	MAX4430EUK	MAX	OA	$V_{DD} = \pm 5\text{ В}; f_{BD} = 180\text{ МГц}; V_{OS} < 5\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ADMB	MAX4431EUK	MAX	OA	$V_{DD} = \pm 5\text{ В}; f_{BD} = 215\text{ МГц}; V_{OS} < 5\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ADMI	MAX6316LUK26D	MAX	mic	$V_{FR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADMJ	MAX4626EUK	MAX	asw	SPST; $R_{ON} < 120\text{ Ом}; V_{DD} = 1.8...5.5\text{ В}$	SOT23-5	COM • NO • GND • IN • V+
ADMK	MAX4627EUK	MAX	asw	SPST; $R_{ON} < 120\text{ Ом}; V_{DD} = 1.8...5.5\text{ В}$	SOT23-5	COM • NC • GND • IN • V+
ADML	MAX4291EUK	MAX	OA	R-R; $V_{OS} = 1.8...5.0/\pm 0.9... \pm 2.75\text{ В}; f_{BD} = 500\text{ кГц}; V_{OS} < 2.5\text{ мВ}$	SOT23-5	IN+ • VEE • IN- • OUT • VCC
ADM	MAX5360LEUK	MAX	DAC	6-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x60; $V_{DD} = 2.7...3.6\text{ В}; V_{REF} = 2\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADMN	MAX5380LEUK	MAX	DAC	8-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x60; $V_{DD} = 2.7...3.6\text{ В}; V_{REF} = 2\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADMO	MAX5360PEUK	MAX	DAC	6-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x66; $V_{DD} = 2.7...3.6\text{ В}; V_{REF} = 2\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADMP	MAX5380PEUK	MAX	DAC	8-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x66; $V_{DD} = 2.7...3.6\text{ В}; V_{REF} = 2\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADMQ	MAX5361PEUK	MAX	DAC	6-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x66; $V_{DD} = 4.5...5.5\text{ В}; V_{REF} = 4\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADMR	MAX5381PEUK	MAX	DAC	8-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x66; $V_{DD} = 4.5...5.5\text{ В}; V_{REF} = 4\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADMS	MAX5362PEUK	MAX	DAC	6-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x66; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}; V_{REF} = 0.9 \times V_{DD}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADMT	MAX5382PEUK	MAX	DAC	8-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x66; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}; V_{REF} = 0.9 \times V_{DD}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADMU	MAX5361LEUK	MAX	DAC	6-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x60; $V_{DD} = 4.5...5.5\text{ В}; V_{REF} = 4\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADMV	MAX5381LEUK	MAX	DAC	8-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x60; $V_{DD} = 4.5...5.5\text{ В}; V_{REF} = 4\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADMW	MAX5362LEUK	MAX	DAC	6-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x60; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}; V_{REF} = 0.9 \times V_{DD}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADMX	MAX5382LEUK	MAX	DAC	8-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x60; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}; V_{REF} = 0.9 \times V_{DD}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADMY	MAX5360MEUK	MAX	DAC	6-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x62; $V_{DD} = 2.7...3.6\text{ В}; V_{REF} = 2\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADMZ	MAX5380MEUK	MAX	DAC	8-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x62; $V_{DD} = 2.7...3.6\text{ В}; V_{REF} = 2\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADNA	MAX5361MEUK	MAX	DAC	6-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x62; $V_{DD} = 4.5...5.5\text{ В}; V_{REF} = 4\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADNB	MAX5381MEUK	MAX	DAC	8-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x62; $V_{DD} = 4.5...5.5\text{ В}; V_{REF} = 4\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADNC	MAX5362MEUK	MAX	DAC	6-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x62; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}; V_{REF} = 0.9 \times V_{DD}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADND	MAX5382MEUK	MAX	DAC	8-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x62; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}; V_{REF} = 0.9 \times V_{DD}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADNE	MAX5360NEUK	MAX	DAC	6-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x64; $V_{DD} = 2.7...3.6\text{ В}; V_{REF} = 2\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADNF	MAX5380NEUK	MAX	DAC	8-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x64; $V_{DD} = 2.7...3.6\text{ В}; V_{REF} = 2\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADNG	MAX5361NEUK	MAX	DAC	6-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x64; $V_{DD} = 4.5...5.5\text{ В}; V_{REF} = 4\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL
ADNH	MAX5381NEUK	MAX	DAC	8-разр.; $I^2\text{C}$; адрес: 0x64; $V_{DD} = 4.5...5.5\text{ В}; V_{REF} = 4\text{ В}$	SOT23-5	OUT • GND • VDD • SDA • SCL

SOT553

SOT353
SC88ASOT23-5
TSOT23-5

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ADNI	MAX5382NEUK	MAX	DAC	8-разр.; I _{FC} ; адрес: 0x64; V _{DD} =2.7...5.5 В; V _{REF} =0.9xV _{DD}	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADNJ	MAX5382NEUK	MAX	DAC	8-разр.; I _{FC} ; адрес: 0x64; V _{DD} =2.7...5.5 В; V _{REF} =0.9xV _{DD}	SOT23-5	OUT•GND•VDD•SDA•SCL
ADNP	MAX4400AUK	MAX	OA	R-R; V _{DD} =2.5...5.5 В; f _{BD} =800 кГц; V _{OS} <5 мВ	SOT23-5	IN+•VSS•IN-•OUT•VDD
ADNR	MAX6316LUK44C	MAX	mrc	V _{TR} =4.39 В; V _{DD} =1...5.5 В; I _{CC} <20 мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•WDI•VCC
ADNS	MAX6318LUK26	MAX	mrc	V _{TR} =2.63 В; V _{DD} =1...5.5 В; I _{CC} <20 мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•WDI•VCC
ADNT	MAX6509CAUK	MAX	tempsw	V _{CC} =2.7...5.5 В; T _{TH} =-40...+125 °C; I _{CC} <165 мкА	SOT23-5	SET•GND•OUT•HYST•VCC
ADNU	MAX6509HAUK	MAX	tempsw	V _{CC} =2.7...5.5 В; T _{TH} =-40...+125 °C; I _{CC} <165 мкА	SOT23-5	SET•GND•OUT•HYST•VCC
ADNV	MAX9040AEUK	MAX	cmp+vref	R-R; V _{OS} <±7 мВ; V _{CC} =2.5...5.5 В; V _{REF} =2.048 В; I _{CC} <72 мкА	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•REF•VCC
ADNW	MAX9050AEUK	MAX	cmp+vref	R-R; V _{OS} <±7 мВ; V _{CC} =2.7...5.5 В; V _{REF} =2.500 В; I _{CC} <72 мкА	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•REF•VCC
ADNX	MAX9040BEUK	MAX	cmp+vref	R-R; V _{OS} <±7 мВ; V _{CC} =2.5...5.5 В; V _{REF} =2.048 В; I _{CC} <72 мкА	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•REF•VCC
ADNY	MAX9050BEUK	MAX	cmp+vref	R-R; V _{OS} <±7 мВ; V _{CC} =2.7...5.5 В; V _{REF} =2.500 В; I _{CC} <72 мкА	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•REF•VCC
ADOA	MAX4321EUK	MAX	OA	R-R; V _{DD} =2.4...6.5/±1.2...±3.25 В; f _{BD} =5 МГц; V _{OS} <3.5 мВ	SOT23-5	OUT•VCC•IN+•IN-•VEE
ADOB	MAX4645EUK	MAX	asw	SPST; R _{ON} <3 Ом; V _{DD} =1.8...5.5 В	SOT23-5	COM•NO•GND•IN•V+
ADOC	MAX4646EUK	MAX	asw	SPST; R _{ON} <3 Ом; V _{DD} =1.8...5.5 В	SOT23-5	COM•NC•GND•IN•V+
ADOD	MAX6320PUK26C	MAX	mrc	V _{TR} =2.63 В; V _{DD} =1...5.5 В; I _{CC} <20 мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•WDI•VCC
ADOE	MAX4568EUK	MAX	asw	SPST; R _{ON} <75 Ом; V _{DD} =1.8...12 В	SOT23-5	COM•NO•GND•IN•V+
ADOF	MAX4569EUK	MAX	asw	SPST; R _{ON} <75 Ом; V _{DD} =1.8...12 В	SOT23-5	COM•NC•GND•IN•V+
ADOG	MAX4376TAUK	MAX	CSA	V _{DD} =3...28 В; Gain=20; I _{CC} <2.2 мА	SOT23-5	OUT•GND•VCC•RS+•RS-
ADOH	MAX4376FAUK	MAX	CSA	V _{DD} =3...28 В; Gain=50; I _{CC} <2.2 мА	SOT23-5	OUT•GND•VCC•RS+•RS-
ADOI	MAX4376HAUK	MAX	CSA	V _{DD} =3...28 В; Gain=100; I _{CC} <2.2 мА	SOT23-5	OUT•GND•VCC•RS+•RS-
ADDJ	MAX9031AUK	MAX	cmp	R-R; V _{OS} <±5 мВ; V _{DD} =2.5...5.5 В; I _{DD} <55 мкА	SOT23-5	IN+•VSS•IN-•OUT•VDD
ADDK	MAX6316LUK46C	MAX	mrc	V _{TR} =4.63 В; V _{DD} =1...5.5 В; I _{CC} <20 мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•WDI•VCC
ADDL	MAX4412EUK	MAX	OA	R-R; V _{DD} =2.7...5.5 В; f _{BD} =500 МГц; V _{OS} <9 мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ADDM	MAX6319MHUK29	MAX	mrc	V _{TR} =2.93 В; V _{DD} =1...5.5 В; I _{CC} <20 мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•MR•VCC
ADDP	MAX6319MHUK46	MAX	mrc	V _{TR} =4.63 В; V _{DD} =1...5.5 В; I _{CC} <20 мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•MR•VCC
ADOR	MAX9100EUK	MAX	cmp	R-R; V _{OS} <±20 мВ; V _{CC} =1...5.5 В; I _{CC} <13 мкА	SOT23-5	OUT•GND•IN+•IN-•VCC
ADOS	MAX9101EUK	MAX	cmp	V _{OS} <±20 мВ; V _{CC} =1...5.5 В; I _{CC} <13 мкА	SOT23-5	OUT•GND•IN+•IN-•VCC
ADOT	MAX4434EUK	MAX	OA	V _{DD} =±5 В; f _{BD} =150 МГц; Gain=1; V _{OS} <3.5 мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ADOU	MAX4435EUK	MAX	OA	V _{DD} =±5 В; f _{BD} =150 МГц; Gain=5; V _{OS} <3.5 мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ADOV	MAX4452EUK	MAX	OA	R-R; V _{DD} =2.7...5.25 В; f _{BD} =200 МГц; V _{OS} <12 мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ADOW	MAX4352EUK	MAX	OA	R-R; V _{DD} =2.7...5.25 В; f _{BD} =80 МГц; V _{OS} <12 мВ	SOT23-5	OUT•VEE•IN+•IN-•VCC
ADOX	MAX1735EUK25	MAX	reg	LDO; V _{IN} =-2.5...-6.5 В; V _{OUT} =-2.5/-1.25...-5.5 В; I _{OUT} =200 мА	SOT23-5	GND•IN•SHDN•SET•OUT
ADOY	MAX1735EUK30	MAX	reg	LDO; V _{IN} =-2.5...-6.5 В; V _{OUT} =-3.0/-1.25...-5.5 В; I _{OUT} =200 мА	SOT23-5	GND•IN•SHDN•SET•OUT
ADOZ	MAX1735EUK50	MAX	reg	LDO; V _{IN} =-2.5...-6.5 В; V _{OUT} =-5.0/-1.25...-5.5 В; I _{OUT} =200 мА	SOT23-5	GND•IN•SHDN•SET•OUT
ADPC	MAX6321HPUK25	MAX	mrc	V _{TR} =2.463 В; V _{DD} =1...5.5 В; I _{CC} <20 мкА	SOT23-5	RES•GND•RES•WDI•VCC
ADPD	MAX9021AUK	MAX	cmp	R-R; V _{OS} <±8 мВ; V _{DD} =2.5...5.5 В; I _{DD} <5 мкА	SOT23-5	IN+•VSS•IN-•OUT•VDD
ADPE	MAX4484AUK	MAX	OA	R-R; V _{DD} =2.7...5.5 В; f _{BD} =7 МГц; V _{OS} <9 мВ	SOT23-5	IN+•VSS•IN-•OUT•VDD
ADPF	MAX6317HUK46B	MAX	mrc	V _{TR} =4.63 В; V _{DD} =1...5.5 В; I _{CC} <20 мкА	SOT23-5	RES•GND•MR•WDI•VCC
ADPG	MAX4493AUK	MAX	OA	R-R; V _{DD} =±2.25...±5.5 В; f _{BD} =5 МГц; V _{OS} <10 мВ	SOT23-5	IN+•VEE•IN-•OUT•VCC
ADPH	MAX4470EUK	MAX	OA	R-R; V _{DD} =1.8...5.5 В; f _{BD} =9 кГц; I _{CC} <1.2 мкА; V _{OS} <7 мВ	SOT23-5	IN+•VSS•IN-•OUT•VDD
ADPI	MAX4464EUK	MAX	OA	R-R; V _{DD} =1.8...5.5 В; f _{BD} =40 кГц; I _{CC} <1.2 мкА; V _{OS} <7 мВ	SOT23-5	IN+•VSS•IN-•OUT•VDD
ADPJ	MAX4480AUK	MAX	OA	R-R; V _{DD} =2.5...5.5 В; I _{CC} <100 мкА; V _{OS} <5 мВ	SOT23-5	IN+•VSS•IN-•OUT•VDD



SOT23-5 **SOT353**
TSOT23-5 **SC88A**



SOT555

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ADPP	MAX6823VUK	MAX	mrc+wdt	$V_{FR} = 1.58\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 30\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADPQ	MAX6821LUK	MAX	mrc+wdt	$V_{FR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 30\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADPR	MAX6822WUK	MAX	mrc+wdt	$V_{FR} = 1.67\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 30\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADPS	MAX6824ZUK	MAX	mrc+wdt	$V_{FR} = 2.32\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 30\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VCC
ADPT	MAX6825TUK	MAX	mrc+wdt	$V_{FR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 30\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VCC
ADPU	MAX6352WJK	MAX	mrc	$V_{FR1} = 3.08\text{ В}; V_{FR2} = 1.67\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADPV	MAX6353SVUK	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.93\text{ В}; V_{FR2} = 1.58\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADPW	MAX6354UWUK	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.78\text{ В}; V_{FR2} = 1.67\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADOF	MAX11722EZK	MAX	dcdc	$V_{IN} = 0.8...5.5\text{ В}; V_{OUT} = 2...5.5\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	BATT • GND • FB • OUT • LX
ADOG	MAX11723EZK	MAX	dcdc	$V_{IN} = 0.8...5.5\text{ В}; V_{OUT} = 2...5.5\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	SOT23-5	BATT • GND • FB • OUT • LX
ADQH	MAX11724EZK27	MAX	dcdc	$V_{IN} = 0.8...5.5\text{ В}; V_{OUT} = 2.7\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	BATT • GND • FB • OUT • LX
ADQI	MAX11724EZK30	MAX	dcdc	$V_{IN} = 0.8...5.5\text{ В}; V_{OUT} = 3\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	SOT23-5	BATT • GND • FB • OUT • LX
ADQJ	MAX11724EZK33	MAX	dcdc	$V_{IN} = 0.8...5.5\text{ В}; V_{OUT} = 3.3\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	BATT • GND • FB • OUT • LX
ADQU	MAX6354LTUK	MAX	mrc	$V_{FR1} = 4.63\text{ В}; V_{FR2} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADQK	MAX11724EZK50	MAX	dcdc	$V_{IN} = 0.8...5.5\text{ В}; V_{OUT} = 5\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	BATT • GND • FB • OUT • LX
ADOK	MAX6501UKP125	MAX	tempsw	$V_{CC} = 2.7...5.5\text{ В}; T_{TH} = +125\text{ °C}; I_{CC} < 85\text{ мкА}$	SOT23-5	GND • GND • HYST • VCC • TOWER
ADQL	MAX6821ZUK	MAX	mrc+wdt	$V_{FR} = 2.32\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 30\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADQM	MAX6825YUK	MAX	mrc+wdt	$V_{FR} = 2.19\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 30\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VCC
ADOM	MAX8867ZK25	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5\text{ В}; V_{OUT} = 2.5\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQO	MAX8867ZK28	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5\text{ В}; V_{OUT} = 2.8\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADOP	MAX8867ZK29	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5\text{ В}; V_{OUT} = 2.84\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQP	MAX9140EUK	MAX	cmp	$V_{OS1} < 4.5\text{ мВ}; V_{CC} = 2.7...5.5\text{ В}; I_{CC} < 300\text{ мкА}$	SOT23-5	OUT • GND • IN • IN • VCC
ADQQ	MAX5466EUK	MAX	Dpot	32 позиции; $10\text{ кОм}; V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-5	VDD • GND • U/D • CS • H
ADQK	MAX8867ZK30	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5\text{ В}; V_{OUT} = 3.0\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADOR	MAX8867ZK32	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5\text{ В}; V_{OUT} = 3.15\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQS	MAX8867ZK33	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5\text{ В}; V_{OUT} = 3.3\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADOT	MAX8867ZK36	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5\text{ В}; V_{OUT} = 3.6\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADOV	MAX8867ZK50	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5\text{ В}; V_{OUT} = 5.0\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQW	MAX6352SVUK	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.93\text{ В}; V_{FR2} = 1.58\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADQX	MAX8868ZK25	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5\text{ В}; V_{OUT} = 2.5\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQY	MAX6353RVUK	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.63\text{ В}; V_{FR2} = 1.58\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADQX	MAX8868ZK28	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5\text{ В}; V_{OUT} = 2.8\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQY	MAX6354SWJK	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.93\text{ В}; V_{FR2} = 1.67\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADQY	MAX8868ZK29	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5\text{ В}; V_{OUT} = 2.84\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADQZ	MAX6354RVUK	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.63\text{ В}; V_{FR2} = 1.58\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADQZ	MAX8868ZK30	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5\text{ В}; V_{OUT} = 3.0\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADRA	MAX4350EUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 4.5...5.5\text{ В}; f_{BD} = 210\text{ МГц}; V_{OS1} < 26\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT • VEE • IN+ • IN- • VCC
ADRA	MAX8868ZK32	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5\text{ В}; V_{OUT} = 3.15\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADRB	MAX6316MUK46A	MAX	mrc	$V_{FR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1...5.5\text{ В}; I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VCC
ADRB	MAX8868ZK33	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5\text{ В}; V_{OUT} = 3.3\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADRC	MAX6353UVUK	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.78\text{ В}; V_{FR2} = 1.58\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-5	RST • GND • MR • VCC2 • VCC1
ADRC	MAX8868ZK36	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...6.5\text{ В}; V_{OUT} = 3.6\text{ В}; I_{OUT} = 150\text{ мА}$	TSOT23-5	SHDN • GND • IN • OUT • BP
ADRD	MAX4465EUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.4...5.5\text{ В}; f_{BD} = 200\text{ кГц}; I_{CC} < 60\text{ мкА}; V_{OS1} < 5\text{ мВ}$	SOT23-5	IN+ • GND • IN- • OUT • VDD

SOT553

SOT353
SC88ASOT23-5
TSOT23-5

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
ADRD	MAX88682K50	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...6.5\text{В}$; $V_{OUT}=5.0\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$	TSOT23-5	SHDN•GND•IN•OUT•BP
ADRE	MAX4466EUK	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.4...5.5\text{В}$; $I_{DD}=200\text{mA}$; $I_{CC}<60\text{mA}$; $V_{OS}<5\text{mВ}$	SOT23-5	IN•GND•IN•OUT•VCC
ADUD	MAX6502UKP125	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.7...5.5\text{В}$; $T_{TH}=+125\text{°C}$; $I_{CC}<85\text{mA}$	SOT23-5	GND•GND•HYST•VCC•TOVER
AEDA	AD8631ART	AD	OA	$f_{BD}=5\text{MГц}$; $P_D=3\text{mВт}$; $V_{DD}=1.8...6\text{В}$	SOT23-5	OUT A•V•+IN A•-IN A•V+
ALW	TPS62208DBV	TI	dc/dc	$V_{IN}=2.5...6.0\text{В}$; $V_{OUT}=1.875\text{В}$; $I_{OUT}=300\text{mA}$	SOT23-5	VI•GND•EN•FB•SW
AOH	AD8515AKSZ	AD	OA	$f_{BD}=5\text{MГц}$; $P_D=3\text{mВт}$; $V_{DD}=1.8...5\text{В}$	SOT353, SC88A	OUT•V•+IN•-IN•V+
AOH	AD8515ARTZ	AD	OA	$f_{BD}=5\text{MГц}$; $P_D=3\text{mВт}$; $V_{DD}=1.8...5\text{В}$	SOT23-5	OUT•V•+IN•-IN•V+
AQ	AN1433SSM	PAN	reg	$V_{IN}=1.25...14\text{В}$; $I_{OUT}<20\text{mA}$; $V_{OUT}=1.25...15\text{В}$	SOT553, EMT5	VCC•ANODE•CATHODE•n.c.•REF
ASA	AD8565AKS	AD	OA	$f_{BD}=5\text{MГц}$; $P_D=12\text{mВт}$; $V_{DD}=4.5...16\text{В}$	SOT353, SC88A	OUT•V+•+IN•-IN•V-
B3A	AD8605ART	AD	OA	$f_{BD}=10\text{MГц}$; $P_D=7\text{mВт}$; $V_{DD}=2.7...5.5\text{В}$	SOT23-5	OUT•V•+IN•-IN•V+
B3A#	AD8605ARTZ	AD	OA	$f_{BD}=10\text{MГц}$; $P_D=7\text{mВт}$; $V_{DD}=2.7...5.5\text{В}$	SOT23-5	OUT•V•+IN•-IN•V+
B43	OPA343NA	TI	OA	R-R; $V_{DD}=2.5...5.5\text{В}$; $f_{BD}=5.5\text{MГц}$; $I_S=1.4\text{mA}$; $V_{OS}<28\text{mВ}$	SOT23-5	OUT•V•+IN•-IN•V+
B9A	AD8627AKS	AD	OA	$f_{BD}=5\text{MГц}$; $P_D=25\text{mВт}$; $V_{DD}=5...26/±2.5...±13\text{В}$	SOT353, SC88A	OUT A•V•+IN•-IN•V+
BA	AN8018RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=2.8\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=1.8\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BB	AN8019RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=2.9\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=1.9\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BC	AN8020RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=3.0\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=2.0\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BD	AN8021RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=3.1\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=2.1\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BDA	AD8515AKS	AD	OA	$f_{BD}=5\text{MГц}$; $P_D=3\text{mВт}$; $V_{DD}=1.8...5\text{В}$	SOT353, SC88A	OUT•V•+IN•-IN•V+
BDA	AD8515ARTZ	AD	OA	$f_{BD}=5\text{MГц}$; $P_D=3\text{mВт}$; $V_{DD}=1.8...5\text{В}$	SOT23-5	OUT•V•+IN•-IN•V+
BE	AN8022RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=3.2\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=2.2\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BF	AN8028RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=3.8\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=2.8\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BG	AN8029RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=3.9\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=2.9\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BH	AN8030RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=4.0\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=3.0\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BJ	AN8031RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=4.1\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=3.1\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BK	AN8032RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=4.2\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=3.2\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BL	AN8033RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=4.3\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=3.3\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BM	AN8034RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=4.4\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=3.4\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BN	AN8035RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=4.5\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=3.5\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BP	AN8036RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=4.6\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=3.6\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BQ	AN8048RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=5.8\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=4.8\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BR	AN8049RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=5.9\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=4.9\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BS	AN8050RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=6.0\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=5.0\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BT	AN8051RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=6.1\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=5.1\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BU	AN8052RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=6.2\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=5.2\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
BW	AN8025RMS	PAN	reg	LDO; $V_{IN}=3.5\text{В}$; $I_{OUT}=150\text{mA}$; $V_{OUT}=2.5\text{В}$	SOT23-5	CONT•GND•n.c.•OUT•IN
C1	FMC1A	ROHM	Dpnp/npn	$V_{CC}=50\text{В}$; $I_{OUT}=100\text{mA}$; $P_D=300\text{mВт}$; $h_{21}>56$	SOT23-5	C1•C2•E2, B2•B1•E1
C1	UMC1N	ROHM	Dpnp/npn	$V_{CC}=50\text{В}$; $I_{OUT}=100\text{mA}$; $P_D=150\text{mВт}$; $h_{21}>56$	SOT353, SC88A	E1•B1•E2, B2•C2•C1
C12	LMV331M5	NS	cmp	$V_{OS}<7\text{mВ}$; $V_{DD}=2.7...5\text{В}$; $I_{CC}<100\text{mA}$	SOT23-5	+IN•V•-IN•OUT•V+
C13	LMV331M7	NS	cmp	$V_{OS}<7\text{mВ}$; $V_{DD}=2.7...5\text{В}$; $I_{CC}<100\text{mA}$	SOT353, SC88A	+IN•V•-IN•OUT•V+
C2	EMC2	ROHM	Dpnp/npn	$V_{CC}=50\text{В}$; $I_{OUT}=100\text{mA}$; $P_D=150\text{mВт}$; $h_{21}>56$; $22\text{ k}\Omega\text{M}/22\text{ k}\Omega\text{M}$	SOT553, EMT5	E1•B1•E2, B2•C2•C1
C2	FMC2A	ROHM	Dpnp/npn	$V_{CC}=50\text{В}$; $I_{OUT}=100\text{mA}$; $P_D=300\text{mВт}$; $h_{21}>56$; $22\text{ k}\Omega\text{M}/22\text{ k}\Omega\text{M}$	SOT23-5	C1•C2•E2, B2•B1•E1
C2	UMC2N	ROHM	Dpnp/npn	$V_{CC}=50\text{В}$; $I_{OUT}=100\text{mA}$; $P_D=150\text{mВт}$; $h_{21}>56$; $22\text{ k}\Omega\text{M}/22\text{ k}\Omega\text{M}$	SOT353, SC88A	E1•B1•E2, B2•C2•C1



SOT23-5
TSOT23-5



SOT553

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
C3	FMC3A	ROHM	Dnpn/npn	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•E2, B2•B1•E1
C3	UMCSN	ROHM	Dnpn/npn	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	E1•B1•E2, B2•C2•C1
C4	FMC4A	ROHM	Dnpn/npn	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $47\text{ кОм}/47\text{ кОм}; 47\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•E2, B2•B1•E1
C4	UMC4N	ROHM	Dnpn/npn	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $47\text{ кОм}/47\text{ кОм}; 47\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	E1•B1•E2, B2•C2•C1
C5	FMC5A	ROHM	Dnpn/npn	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $47\text{ кОм}/47\text{ кОм}; 4.7\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•E2, B2•B1•E1
C5	UMCSN	ROHM	Dnpn/npn	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $47\text{ кОм}/47\text{ кОм}; 4.7\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	E1•B1•E2, B2•C2•C1
C6	FMC6A	ROHM	Dnpn/npn	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $100\text{ кОм}/100\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•E2, B2•B1•E1
C6	UMC6N	ROHM	Dnpn/npn	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $100\text{ кОм}/100\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	E1•B1•E2, B2•C2•C1
C7	FMC7A	ROHM	Dnpn/npn	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 56$	SOT23-5	C1•C2•E2, B2•B1•E1
C7	UMCTN	ROHM	Dnpn/npn	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56$	SOT353, SC88A	E1•B1•E2, B2•C2•C1
CGA	AD7415ART	AD	dts	10-паэр.; SMBus/I ² C; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-5	AS•GND•VDD•SDA•SCL
CGB	AD7415ART	AD	dts	10-паэр.; SMBus/I ² C; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-5	AS•GND•VDD•SDA•SCL
D43	OPA743NA	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 3.5...12 \pm 1.75...36\text{ В}; f_{BD} = 7\text{ МГц};$ $I_S = 1.7\text{ мА}; V_{OS} \leq 7\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT•V-•+IN•-IN•V+
D53	OPA353NA	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}; f_{BD} = 44\text{ МГц}; I_S = 9\text{ мА};$ $V_{OS} < 10\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT•V-•+IN•-IN•V+
DNC	ADP3309ART-2.7	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.8...12\text{ В}; I_{OUT} = 100\text{ мА}; V_{OUT} = 2.7\text{ В}$	SOT23-5	IN•GND•SD•ERR/n. c. •OUT
DPC	ADP3309ART-3	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.8...12\text{ В}; I_{OUT} = 100\text{ мА}; V_{OUT} = 3\text{ В}$	SOT23-5	IN•GND•SD•ERR/n. c. •OUT
DRC	ADP3309ART-3.3	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.8...12\text{ В}; I_{OUT} = 100\text{ мА}; V_{OUT} = 3.3\text{ В}$	SOT23-5	IN•GND•SD•ERR/n. c. •OUT
DTC	ADP3309ART-3.6	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.8...12\text{ В}; I_{OUT} = 100\text{ мА}; V_{OUT} = 3.6\text{ В}$	SOT23-5	IN•GND•SD•ERR/n. c. •OUT
DVC	ADP3309ART-2.85	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.8...12\text{ В}; I_{OUT} = 100\text{ мА}; V_{OUT} = 2.85\text{ В}$	SOT23-5	IN•GND•SD•ERR/n. c. •OUT
DWC	ADP3309ART-2.9	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.8...12\text{ В}; I_{OUT} = 100\text{ мА}; V_{OUT} = 2.9\text{ В}$	SOT23-5	IN•GND•SD•ERR/n. c. •OUT
E37	OPA137NA	TI	OA	$V_{DD} = 4.5...36 \pm 2.25...18\text{ В}; I_S = 320\text{ мА};$ $V_{OS} < 7\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT•V-•+IN•-IN•V+
EV	1SV241	SANY O	pin x2	$V_A > 50\text{ В}; I_C < 50\text{ мА}; V_F (I_F = 50\text{ мА}) = 0.95\text{ В};$ $I_S < 0.1\text{ мА}$	SOT23-5	A1•n. c. •A2•K2•K1
G1	EMG1	ROHM	Dnpn x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $22\text{ кОм}/22\text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G1	FMG1A	ROHM	Dnpn x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $22\text{ кОм}/22\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
G1	UMG1N	ROHM	Dnpn x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $22\text{ кОм}/22\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G10	UMG10N	ROHM	Dnpn x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 33;$ $R2/R1 = 10$	SOT353, SC88A	C1•C2•B2•E1, E2•B1
G11	EMG11	ROHM	Dnpn x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $R2/R1 = 21$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G11	FMG11A	ROHM	Dnpn x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $R2/R1 = 21$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
G11	UMG11N	ROHM	Dnpn x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $R2/R1 = 21$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G2	FMG2A	ROHM	Dnpn x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $47\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
G2	UMG2N	ROHM	Dnpn x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_{COUT} = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ $47\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G3	IMG3A	ROHM	Dnpn x2	$V_{CE} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 100;$ $R1\ 4.7\text{ кОм}$	SOT23-5	B2•B1•C2•E1, E1•C1
G37	OPA337NA	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5\text{ В}; f_{BD} = 3\text{ МГц}; I_S = 1.2\text{ мА};$ $V_{OS} < 3.5\text{ мВ}$	SOT23-5	OUT•V-•+IN•-IN•V+

SOT553

SOT353
SC88ASOT23-5
TSOT23-5

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
G4	EMG4	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_{T1} 10\text{ кОм}$	SOT553, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G4	FMG4A	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_{T1} 10\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
G4	UMG4N	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_{T1} 10\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G5	EMG5	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $10\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G5	FMG5A	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $10\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
G5	UMG5N	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $10\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G5	UMG5N	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{CM}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>68;$ $R2/R1=4.7$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G6	EMG6	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_{T1} 47\text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G6	FMG6A	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_{T1} 47\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
G6	UMG6N	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_{T1} 47\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G6	UMG6N	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_1=47\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G7	FMG7A	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>100$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
G7	UMG7N	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G7	UMG7N	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_1=10\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1•E2•C2•C1, B2
G8	EMG8	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $4.7\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G8	FMG8A	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $4.7\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
G8	UMG8N	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $4.7\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G8	UMG8N	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{CM}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>80;$ $R2/R1=10$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G9	EMG9	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{CM}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>56;$ $10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
G9	FMG9A	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{CM}=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>56;$ $10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
G9	UMG9N	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{CM}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>56;$ $10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
H0A	AD8031ART	AD	OA	$f_{80}=80\text{ МГц}; P_D=16\text{ мВт}; V_{DD}=2.7...1.2\text{ В}$	SOT23-5	VOUT•-VS•+IN•-IN•+VS
H0D	AD8061ARTZ	AD	OA	$f_{80}=320\text{ МГц}; P_D=75\text{ мВт}; V_{DD}=2.7...8\text{ В}$	SOT23-5	VOUT•-VS•+IN•-IN•+VS
H1A	AD8005AR	AD	OA	$f_{80}=270\text{ МГц}; P_D=4\text{ мВт}; V_{DD}=±3...±6\text{ В}$	SOT23-5	OUT•-VS•+IN•-IN•+VS
H2A	AD8051ART	AD	OA	$f_{80}=110\text{ МГц}; P_D=60\text{ мВт}; V_{DD}=±3...12\text{ В}$	SOT23-5	VOUT•-VS•+IN•-IN•+VS
H3A	AD8055ART	AD	OA	$f_{80}=300\text{ МГц}; P_D=40\text{ мВт}; V_{DD}=±4...±6\text{ В}$	SOT23-5	VOUT•-VS•+IN•-IN•+VS
H3B	AD8033AKS	AD	OA	$f_{80}=80\text{ МГц}; P_D=65\text{ мВт}; V_{DD}=5...24\text{ В}$	SOT353, SC88A	VOUT•-VS•+IN•-IN•+VS
H4	EMH4	ROHM	Dnprn x2	$V_{CC0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_{T1} 10\text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
H7A	AD8057ART	AD	OA	$f_{80}=325\text{ МГц}; P_D=70\text{ мВт}; V_{DD}=3...12\text{ В}$	SOT23-5	VOUT•-VS•+IN•-IN•+VS
HAA	AD8014ART	AD	OA	$f_{80}=480\text{ МГц}; P_D=8\text{ мВт}; V_{DD}=±2.25...±6\text{ В}$	SOT23-5	VOUT•-VS•+IN•-IN•+VS
HEA	AD8001ART	AD	OA	$f_{80}<880\text{ МГц}; P_D=50\text{ мВт}; V_{DD}=±3...±6\text{ В}$	SOT23-5	VOUT•-VS•+IN•-IN•+VS
HGA	AD8061ART	AD	OA	$f_{80}=320\text{ МГц}; P_D=75\text{ мВт}; V_{DD}=2.7...8\text{ В}$	SOT23-5	VOUT•-VS•+IN•-IN•+VS
HRA	AD8065ART	AD	OA	$f_{80}=145\text{ МГц}; P_D=150\text{ мВт}; V_{DD}=5...24\text{ В}$	SOT23-5	VOUT•-VS•+IN•-IN•+VS
HRAF	AD8065ARTZ	AD	OA	$f_{80}=145\text{ МГц}; P_D=150\text{ мВт}; V_{DD}=5...24\text{ В}$	SOT23-5	VOUT•-VS•+IN•-IN•+VS
HTA	AD8007AKS	AD	OA	$f_{80}=650\text{ МГц}; P_D=120\text{ мВт}; V_{DD}=5...12\text{ В}$	SOT353, SC88A	VOUT•-VS•+IN•-IN•+VS



SOT23-5 **SOT353**
TSOT23-5 **SC88A**



SOT553

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
HUA	AD8038AKS	AD	OA	$f_{BD} = 350 \text{ МГц}$; $P_D = 18 \text{ мВт}$; $V_{DD} = 3...12 \text{ В}$	SOT353, SC88A	VOUT • -VS • +IN • -IN • +VS
HVA	AD8091ART	AD	OA	$f_{BD} = 110 \text{ МГц}$; $P_D = 60 \text{ мВт}$; $V_{DD} = 3...12 \text{ В}$	SOT23-5	VOUT • -VS • +IN • -IN • +VS
HVA#	AD8091ARTZ	AD	OA	$f_{BD} = 110 \text{ МГц}$; $P_D = 60 \text{ мВт}$; $V_{DD} = 3...12 \text{ В}$	SOT23-5	VOUT • -VS • +IN • -IN • +VS
J36	OPA336NJ	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 2.3...5.5 \text{ В}$; $I_S = 42 \text{ мкА}$; $V_{OS} \leq 125 \text{ мВ}$	SOT23-5	OUT • V- • +IN • -IN • +V+
K1	UM5K1N	ROHM	nMOS x2	$V_{DS} = 30 \text{ В}$; $I_D = 100 \text{ мА}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $R_{\theta(Son)} < 13 \text{ }^\circ\text{C/W}$	SOT353, SC88A	G1 • S1, S2 • G2 • D2 • D1
L1	UML1N	ROHM	pn+di	$V_{CBO} = 60 \text{ В}$; $I_C = 150 \text{ мА}$; $I_{H1} > 120$; $V_R = 80 \text{ В}$; $I_F = 100 \text{ мА}$; $V_F(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}$	SOT353, SC88A	A • E • B • C • K
L2	UML2N	ROHM	npn+di	$V_{CBO} = 60 \text{ В}$; $I_C = 150 \text{ мА}$; $I_{H1} > 120$; $V_R = 80 \text{ В}$; $I_F = 100 \text{ мА}$; $V_F(I_F = 100 \text{ мА}) < 1.2 \text{ В}$	SOT353, SC88A	A • E • B • C • K
LA	MC74LCX1G14	ON	Schminv	$V_{CC} = 2.0...3.6 \text{ В}$; $I_{OUI} = 24 \text{ мА}$	SOT23-5	n. c. • INA • GND • OUT Y • VCC
LAG	MC78LC15NTR	ON	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...12 \text{ В}$; $V_{OUI} = 1.5 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LAH	MC78LC18NTR	ON	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...12 \text{ В}$; $V_{OUI} = 1.8 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LAI	MC78LC25NTR	ON	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...12 \text{ В}$; $V_{OUI} = 2.5 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LAJ	MC78LC27NTR	ON	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...12 \text{ В}$; $V_{OUI} = 2.7 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LAK	MC78LC28NTR	ON	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...12 \text{ В}$; $V_{OUI} = 2.8 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LAL	MC78LC30NTR	ON	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...12 \text{ В}$; $V_{OUI} = 3.0 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LAM	MC78LC33NTR	ON	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...12 \text{ В}$; $V_{OUI} = 3.3 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LAN	MC78LC50NTR	ON	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...12 \text{ В}$; $V_{OUI} = 5.0 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LDE	ADP3309ART-2.5	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.8...12 \text{ В}$; $I_{OUI} = 100 \text{ мА}$; $V_{OUI} = 2.5 \text{ В}$	SOT23-5	IN • GND • SD • ERR/n. c. • OUT
LEC	MC78LC40NTR	ON	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...12 \text{ В}$; $V_{OUI} = 4.0 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	GND • VIN • VOUT • n. c. • n. c.
LV	1SV265	SANYO	pin x2	$V_A > 50 \text{ В}$; $I_C < 50 \text{ мА}$; $V_F(I_F = 50 \text{ мА}) = 0.91 \text{ В}$; $I_S < 0.1 \text{ мкА}$	SOT23-5	A1 • n. c. • A2 • K2 • K1
OAOI	OPA842IDBV	TI	OA	$V_{DD} = \pm 5... \pm 6 \text{ В}$; $f_{BD} = 200 \text{ МГц}$; $I_S = 22.5 \text{ мА}$; $V_{OS} < \pm 1.5 \text{ мВ}$	SOT23-5	OUT • V- • +IN • -IN • +V+
PAPI	TPS3823-25DBV	TI	mic+wdt	$V_{RH} = 2.25 \text{ В}$; $V_{DD} = 1.1...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 25 \text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PAOI	TPS3823-30DBV	TI	mic+wdt	$V_{RH} = 2.63 \text{ В}$; $V_{DD} = 1.1...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 25 \text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PARI	TPS3823-33DBV	TI	mic+wdt	$V_{RH} = 2.93 \text{ В}$; $V_{DD} = 1.1...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 25 \text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PASI	TPS3823-50DBV	TI	mic+wdt	$V_{RH} = 4.55 \text{ В}$; $V_{DD} = 1.1...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 25 \text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PATI	TPS3824-25DBV	TI	mic+wdt	$V_{RH} = 2.25 \text{ В}$; $V_{DD} = 1.1...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 25 \text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VDD
PAUI	TPS3824-30DBV	TI	mic+wdt	$V_{RH} = 2.63 \text{ В}$; $V_{DD} = 1.1...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 25 \text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VDD
PAVI	TPS3824-33DBV	TI	mic+wdt	$V_{RH} = 2.93 \text{ В}$; $V_{DD} = 1.1...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 25 \text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VDD
PAWI	TPS3824-50DBV	TI	mic+wdt	$V_{RH} = 4.55 \text{ В}$; $V_{DD} = 1.1...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 25 \text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RES • WDI • VDD
PCPI	TPS77001DBV	TI	reg	LDO; $V_{IN} = 2.7...10.0 \text{ В}$; $V_{OUI} = 1.2...5.5 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCOI	TPS77012DBV	TI	reg	LDO; $V_{IN} = 2.7...10.0 \text{ В}$; $V_{OUI} = 1.2 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCOI	TPS77018DBV	TI	reg	LDO; $V_{IN} = 2.7...10.0 \text{ В}$; $V_{OUI} = 1.8 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCRI	TPS77015DBV	TI	reg	LDO; $V_{IN} = 2.7...10.0 \text{ В}$; $V_{OUI} = 1.5 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCTI	TPS77025DBV	TI	reg	LDO; $V_{IN} = 2.7...10.0 \text{ В}$; $V_{OUI} = 2.5 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCUI	TPS77027DBV	TI	reg	LDO; $V_{IN} = 2.7...10.0 \text{ В}$; $V_{OUI} = 2.7 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCVI	TPS77028DBV	TI	reg	LDO; $V_{IN} = 2.7...10.0 \text{ В}$; $V_{OUI} = 2.8 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCWI	TPS77030DBV	TI	reg	LDO; $V_{IN} = 2.7...10.0 \text{ В}$; $V_{OUI} = 3.0 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCXI	TPS77033DBV	TI	reg	LDO; $V_{IN} = 2.7...10.0 \text{ В}$; $V_{OUI} = 3.3 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PCYI	TPS77050DBV	TI	reg	LDO; $V_{IN} = 2.7...10.0 \text{ В}$; $V_{OUI} = 5.0 \text{ В}$; $I_{OUI} = 50 \text{ мА}$	SOT23-5	IN • GND • EN • NC/FB • OUT
PDDI	TPS3820-50DBV	TI	mic+wdt	$V_{RH} = 4.55 \text{ В}$; $V_{DD} = 1.1...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 25 \text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PDEI	TPS3820-33DBV	TI	mic+wdt	$V_{RH} = 2.93 \text{ В}$; $V_{DD} = 1.1...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 25 \text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PDFI	TPS3825-50DBV	TI	mic+wdt	$V_{RH} = 4.55 \text{ В}$; $V_{DD} = 1.1...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 25 \text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VDD
PDGI	TPS3825-33DBV	TI	mic+wdt	$V_{RH} = 2.93 \text{ В}$; $V_{DD} = 1.1...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 25 \text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • RES • MR • VDD
PDHI	TPS3828-50DBV	TI	mic+wdt	$V_{RH} = 4.55 \text{ В}$; $V_{DD} = 1.1...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 25 \text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PDII	TPS3828-33DBV	TI	mic+wdt	$V_{RH} = 2.93 \text{ В}$; $V_{DD} = 1.1...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 25 \text{ мкА}$	SOT23-5	RES • GND • MR • WDI • VDD
PHKI	TPS62200DBV	TI	dc/dc	$V_{IN} = 2.5...6.0 \text{ В}$; $V_{OUI} = 0.7...V_{IN} \text{ В}$; $I_{OUI} = 300 \text{ мА}$	SOT23-5	VI • GND • EN • FB • SW
PHLI	TPS62201DBV	TI	dc/dc	$V_{IN} = 2.5...6.0 \text{ В}$; $V_{OUI} = 1.5 \text{ В}$; $I_{OUI} = 300 \text{ мА}$	SOT23-5	VI • GND • EN • FB • SW

SOT553

SOT353
SC88ASOT23-5
TSOT23-5

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
PHMI	TPS62202DBV	TI	dcdc	$V_{IN}=2.5...6.0\text{ B}$; $V_{OUT}=1.8\text{ B}$; $I_{OUT}=300\text{ mA}$	SOT23-5	V•GND•EN•FB•SW
PHNI	TPS62203DBV	TI	dcdc	$V_{IN}=2.5...6.0\text{ B}$; $V_{OUT}=3.3\text{ B}$; $I_{OUT}=300\text{ mA}$	SOT23-5	V•GND•EN•FB•SW
PHSI	TPS62204DBV	TI	dcdc	$V_{IN}=2.5...6.0\text{ B}$; $V_{OUT}=1.6\text{ B}$; $I_{OUT}=300\text{ mA}$	SOT23-5	V•GND•EN•FB•SW
PHTI	TPS62205DBV	TI	dcdc	$V_{IN}=2.5...6.0\text{ B}$; $V_{OUT}=2.5\text{ B}$; $I_{OUT}=300\text{ mA}$	SOT23-5	V•GND•EN•FB•SW
PJGI	TPS62207DBV	TI	dcdc	$V_{IN}=2.5...6.0\text{ B}$; $V_{OUT}=1.2\text{ B}$; $I_{OUT}=300\text{ mA}$	SOT23-5	V•GND•EN•FB•SW
Q2	FMQ2	ROHM	Dnpx x2	$V_{REG}=40\text{ B}$; $I_C=30\text{ mA}$; $P_D=300\text{ mBt}$; $h_{21}>120$; $100\text{ k}\Omega\text{M}/100\text{ k}\Omega\text{M}/200\text{ Om}$	SOT23-5	E2•B2. E2•C1•B1•C2
R02A	LM4130AIM5-2.0	NS	vref	$V_{OUT}=2.0\text{ B}$; ACC=0.05%; 10 ppm/°C	SOT23-5	n.c. • GND • n.c. • VIN • VREF
R02B	LM4130BIM5-2.0	NS	vref	$V_{OUT}=2.0\text{ B}$; ACC=0.2%; 10 ppm/°C	SOT23-5	n.c. • GND • n.c. • VIN • VREF
R02C	LM4130CIM5-2.0	NS	vref	$V_{OUT}=2.0\text{ B}$; ACC=0.1%; 20 ppm/°C	SOT23-5	n.c. • GND • n.c. • VIN • VREF
R02D	LM4130DIM5-2.0	NS	vref	$V_{OUT}=2.0\text{ B}$; ACC=0.4%; 20 ppm/°C	SOT23-5	n.c. • GND • n.c. • VIN • VREF
R02E	LM4130EIM5-2.0	NS	vref	$V_{OUT}=2.0\text{ B}$; ACC=0.5%; 30 ppm/°C	SOT23-5	n.c. • GND • n.c. • VIN • VREF
R03A	LM4130AIM5-2.5	NS	vref	$V_{OUT}=2.5\text{ B}$; ACC=0.05%; 10 ppm/°C	SOT23-5	n.c. • GND • n.c. • VIN • VREF
R03B	LM4130BIM5-2.5	NS	vref	$V_{OUT}=2.5\text{ B}$; ACC=0.2%; 10 ppm/°C	SOT23-5	n.c. • GND • n.c. • VIN • VREF
R03C	LM4130CIM5-2.5	NS	vref	$V_{OUT}=2.5\text{ B}$; ACC=0.1%; 20 ppm/°C	SOT23-5	n.c. • GND • n.c. • VIN • VREF
R03D	LM4130DIM5-2.5	NS	vref	$V_{OUT}=2.5\text{ B}$; ACC=0.4%; 20 ppm/°C	SOT23-5	n.c. • GND • n.c. • VIN • VREF
R03E	LM4130EIM5-2.5	NS	vref	$V_{OUT}=2.5\text{ B}$; ACC=0.5%; 30 ppm/°C	SOT23-5	n.c. • GND • n.c. • VIN • VREF
R04A	LM4130AIM5-4.1	NS	vref	$V_{OUT}=4.1\text{ B}$; ACC=0.05%; 10 ppm/°C	SOT23-5	n.c. • GND • n.c. • VIN • VREF
R04B	LM4130BIM5-4.1	NS	vref	$V_{OUT}=4.1\text{ B}$; ACC=0.2%; 10 ppm/°C	SOT23-5	n.c. • GND • n.c. • VIN • VREF
R04C	LM4130CIM5-4.1	NS	vref	$V_{OUT}=4.1\text{ B}$; ACC=0.1%; 20 ppm/°C	SOT23-5	n.c. • GND • n.c. • VIN • VREF
R04D	LM4130DIM5-4.1	NS	vref	$V_{OUT}=4.1\text{ B}$; ACC=0.4%; 20 ppm/°C	SOT23-5	n.c. • GND • n.c. • VIN • VREF
R04E	LM4130EIM5-4.1	NS	vref	$V_{OUT}=4.1\text{ B}$; ACC=0.5%; 30 ppm/°C	SOT23-5	n.c. • GND • n.c. • VIN • VREF
R0A	ADR318ARJ	AD	vref	$V_{IN}=2.4...15\text{ B}$; $I_{OUT}=5\text{ mA}$; $V_{OUT}=1.8\text{ B}$	SOT23-5	SHDN • VIN • VOUTS • VOUTF • GND
R0A	ADR390AUJZ	AD	vref	$V_{IN}=2.5...15\text{ B}$; $I_{OUT}=5\text{ mA}$; $V_{OUT}=2.048\text{ B}$	TSOT23-5	SHDN • VIN • VOUTS • VOUTF • GND
R0B	ADR390BUJZ	AD	vref	$V_{IN}=2.5...15\text{ B}$; $I_{OUT}=5\text{ mA}$; $V_{OUT}=2.048\text{ B}$	TSOT23-5	SHDN • VIN • VOUTS • VOUTF • GND
R1A	ADR391AUJZ	AD	vref	$V_{IN}=2.5...15\text{ B}$; $I_{OUT}=5\text{ mA}$; $V_{OUT}=2.5\text{ B}$	TSOT23-5	SHDN • VIN • VOUTS • VOUTF • GND
R1B	ADR391BUJZ	AD	vref	$V_{IN}=2.5...15\text{ B}$; $I_{OUT}=5\text{ mA}$; $V_{OUT}=2.5\text{ B}$	TSOT23-5	SHDN • VIN • VOUTS • VOUTF • GND
R1E	ADRO1AKSZ	AD	vref	$V_{IN}=12...40\text{ B}$; $I_{OUT}=10\text{ mA}$; $V_{OUT}=10\text{ B}$	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1E	ADRO1AUJZ	AD	vref	$V_{IN}=12...40\text{ B}$; $I_{OUT}=10\text{ mA}$; $V_{OUT}=10\text{ B}$	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1F	ADRO1BKSZ	AD	vref	$V_{IN}=12...40\text{ B}$; $I_{OUT}=10\text{ mA}$; $V_{OUT}=10\text{ B}$	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1F	ADRO1BUJZ	AD	vref	$V_{IN}=12...40\text{ B}$; $I_{OUT}=10\text{ mA}$; $V_{OUT}=10\text{ B}$	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1G	ADRO2AKSZ	AD	vref	$V_{IN}=7...40\text{ B}$; $I_{OUT}=10\text{ mA}$; $V_{OUT}=5\text{ B}$	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1G	ADRO2AUJZ	AD	vref	$V_{IN}=7...40\text{ B}$; $I_{OUT}=10\text{ mA}$; $V_{OUT}=5\text{ B}$	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1H	ADRO2BKSZ	AD	vref	$V_{IN}=7...40\text{ B}$; $I_{OUT}=10\text{ mA}$; $V_{OUT}=5\text{ B}$	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1H	ADRO2BUJZ	AD	vref	$V_{IN}=7...40\text{ B}$; $I_{OUT}=10\text{ mA}$; $V_{OUT}=5\text{ B}$	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1J	ADRO3AKSZ	AD	vref	$V_{IN}=4.5...40\text{ B}$; $I_{OUT}=10\text{ mA}$; $V_{OUT}=2.5\text{ B}$	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1J	ADRO3AUJZ	AD	vref	$V_{IN}=4.5...40\text{ B}$; $I_{OUT}=10\text{ mA}$; $V_{OUT}=2.5\text{ B}$	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1K	ADRO3BKSZ	AD	vref	$V_{IN}=4.5...40\text{ B}$; $I_{OUT}=10\text{ mA}$; $V_{OUT}=2.5\text{ B}$	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1K	ADRO3BUJZ	AD	vref	$V_{IN}=4.5...40\text{ B}$; $I_{OUT}=10\text{ mA}$; $V_{OUT}=2.5\text{ B}$	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1L	ADRO6AKSZ	AD	vref	$V_{IN}=5...40\text{ B}$; $I_{OUT}=10\text{ mA}$; $V_{OUT}=3\text{ B}$	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1L	ADRO6AUJZ	AD	vref	$V_{IN}=5...40\text{ B}$; $I_{OUT}=10\text{ mA}$; $V_{OUT}=3\text{ B}$	TSOT23-5	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM
R1M	ADRO6BKSZ	AD	vref	$V_{IN}=5...40\text{ B}$; $I_{OUT}=10\text{ mA}$; $V_{OUT}=3\text{ B}$	SOT353, SC88A	TEMP • GND • VIN • VOUT • TRIM



SOT23-5 **SOT353**
TSOT23-5 **SC88A**



SOT553

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
R1M	ADR06BUJZ	AD	vref	$V_{IN}=5...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=3\text{ В}$	TSOT23-5	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
R8A	ADR01AKS	AD	vref	$V_{IN}=12...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=10\text{ В}$	SOT353, SC88A	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
R8A	ADR01AUJ	AD	vref	$V_{IN}=12...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=10\text{ В}$	TSOT23-5	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
R8B	ADR01BKS	AD	vref	$V_{IN}=12...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=10\text{ В}$	SOT353, SC88A	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
R8B	ADR01BUJ	AD	vref	$V_{IN}=12...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=10\text{ В}$	TSOT23-5	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
R9A	ADR02AKS	AD	vref	$V_{IN}=7...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=5\text{ В}$	SOT353, SC88A	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
R9A	ADR02AUJ	AD	vref	$V_{IN}=7...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=5\text{ В}$	TSOT23-5	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
R9B	ADR02BKS	AD	vref	$V_{IN}=7...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=5\text{ В}$	SOT353, SC88A	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
R9B	ADR02BUJ	AD	vref	$V_{IN}=7...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=5\text{ В}$	TSOT23-5	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
RCA	ADR392AUJZ	AD	vref	$V_{IN}=2.5...15\text{ В}; I_{OUT}=5\text{ мА}; V_{OUT}=4.096\text{ В}$	TSOT23-5	SHDN•VIN•VOUTS•VOUTF•GND
RCB	ADR392BUJZ	AD	vref	$V_{IN}=2.5...15\text{ В}; I_{OUT}=5\text{ мА}; V_{OUT}=4.096\text{ В}$	TSOT23-5	SHDN•VIN•VOUTS•VOUTF•GND
RDA	ADR395AUJZ	AD	vref	$V_{IN}=2.5...15\text{ В}; I_{OUT}=5\text{ мА}; V_{OUT}=5\text{ В}$	TSOT23-5	SHDN•VIN•VOUTS•VOUTF•GND
RDB	ADR395BUJZ	AD	vref	$V_{IN}=2.5...15\text{ В}; I_{OUT}=5\text{ мА}; V_{OUT}=5\text{ В}$	TSOT23-5	SHDN•VIN•VOUTS•VOUTF•GND
RFA	ADR03AKS	AD	vref	$V_{IN}=4.5...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=2.5\text{ В}$	SOT353, SC88A	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
RFA	ADR03AUJ	AD	vref	$V_{IN}=4.5...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=2.5\text{ В}$	TSOT23-5	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
RFB	ADR03BKS	AD	vref	$V_{IN}=4.5...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=2.5\text{ В}$	SOT353, SC88A	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
RFB	ADR03BUJ	AD	vref	$V_{IN}=4.5...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=2.5\text{ В}$	TSOT23-5	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
RWA	ADR06AKS	AD	vref	$V_{IN}=5...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=3\text{ В}$	SOT353, SC88A	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
RWA	ADR06AUJ	AD	vref	$V_{IN}=5...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=3\text{ В}$	TSOT23-5	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
RWB	ADR06BKS	AD	vref	$V_{IN}=5...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=3\text{ В}$	SOT353, SC88A	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
RWB	ADR06BUJ	AD	vref	$V_{IN}=5...40\text{ В}; I_{OUT}=10\text{ мА}; V_{OUT}=3\text{ В}$	TSOT23-5	TEMP•GND•VIN•VOUT•TRIM
S00	ADG741BKSZ5	AD	asw	2x SPST; $R_{ON}<4\text{ Ом}; V_{DD}=1.8...5.5\text{ В}$	SOT353, SC88A	D•S•GND•IN•VDD
S01	ADG742BKSZ5	AD	asw	2x SPST; $R_{ON}<4\text{ Ом}; V_{DD}=1.8...5.5\text{ В}$	SOT353, SC88A	D•S•GND•IN•VDD
S1	EMS1	ROHM	pnп x2	$V_{CB0}=60\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>120$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
S1	FMS1A	ROHM	pnп x2	$V_{CB0}=60\text{ В}; I_C=150\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>120$	TSOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
S1	UMS1N	ROHM	pnп x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D(\text{com.})=300\text{ мВт}; h_{21}>120$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
S2	FMS2A	ROHM	pnп x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>120$	TSOT23-5	C1•C2•E2•B1, B2•E1
S2	UMS2N	ROHM	pnп x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D(\text{com.})=300\text{ мВт}; h_{21}>120$	SOT353, SC88A	E1•B1, B2•E2•C2•C1
S3	FMS3	ROHM	pnп x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>120$	SOT23-5	C2•E1, E2•C1•B1•B2
S3B	ADG701BRJ	AD	asw	SPST; $R_{ON}<4\text{ Ом}; V_{DD}=1.8...5.5\text{ В}$	TSOT23-5	D•S•GND•IN•VDD
S4	FMS4	ROHM	pnп x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>120$	TSOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
S47	OPA347SA	TI	OA	R-R; $V_{DD}=2.3...5.5\text{ В}; f_{BD}=350\text{ кГц}; I_S=43\text{ мкА}; V_{OS1}<7\text{ мВ}$	SOT353, SC88A	+IN•V-•-IN•OUT•V+
S48	OPA348AI	TI	OA	R-R; $V_{DD}=2.1...5.5\text{ В}; f_{BD}=1\text{ МГц}; I_S=75\text{ мкА}; V_{OS1}<6\text{ мВ}$	SOT353, SC88A	+IN•V-•-IN•OUT•V+
S4B	ADG702BRJ	AD	asw	SPST; $R_{ON}<4\text{ Ом}; V_{DD}=1.8...5.5\text{ В}$	TSOT23-5	D•S•GND•IN•VDD
T2B	LM20BIM7	NS	ats	$T_{AMB}=-55...130\text{ }^\circ\text{C}; V_{CC}=2.4...5.5\text{ В}; I_{OUT}<10\text{ мА}$	SOT353, SC88A	n. c. •GND•Vo•GND•V+
T2C	LM20CIM7	NS	ats	$T_{AMB}=-55...130\text{ }^\circ\text{C}; V_{CC}=2.4...5.5\text{ В}; I_{OUT}<10\text{ мА}$	SOT353, SC88A	n. c. •GND•Vo•GND•V+

SOT553

SOT353
SC88ASOT23-5
TSOT23-5

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
T5G	TMP35GRT	AD	ats	$T_{AMB} = 10...125^{\circ}\text{C}$; $V_{CC} = 2.7...5.5\text{В}$; $I_{OUT} < 50\text{мкА}$; $ACC = \pm 3^{\circ}\text{C}$	SOT23-5	VOUТ•+VS•n.c. •SHDN•GND
T6G	TMP36GRT	AD	ats	$T_{AMB} = -40...125^{\circ}\text{C}$; $V_{CC} = 2.7...5.5\text{В}$; $I_{OUT} < 50\text{мкА}$; $ACC = \pm 3^{\circ}\text{C}$	SOT23-5	VOUТ•+VS•n.c. •SHDN•GND
T7G	TMP37GRT	AD	ats	$T_{AMB} = 5...100^{\circ}\text{C}$; $V_{CC} = 2.7...5.5\text{В}$; $I_{OUT} < 50\text{мкА}$; $ACC = \pm 3^{\circ}\text{C}$	SOT23-5	VOUТ•+VS•n.c. •SHDN•GND
V0	MC74VHC1G01DF	ON	2-NAND	$V_{CC} = 2.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.7\text{нс}$	SOT353, SC88A	INB•INA•GND•OUTY•VCC
V0	MC74VHC1G01DT	ON	2-NAND	$V_{CC} = 2.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.7\text{нс}$	SOT23-5	INB•INA•GND•OUTY•VCC
V3	MC74VHC1G02DF	ON	2-NOR	$V_{CC} = 2.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.0\text{нс}$	SOT353, SC88A	INB•INA•GND•OUTY•VCC
VA	MC74VHC1G14	ON	Schminv	$V_{CC} = 2.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 4.5\text{нс}$	SOT23-5	n.c. •INA•GND•OUTY•VCC
VAZI	TLV2631DBV	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{В}$; $I_{BD} = 9\text{мГц}$; $V_{OS} < 4.5\text{мВ}$	SOT23-5	OUT•GND•IN+•IN•VDD
VC	MC74VHC1GT14DF	ON	Schminv	$V_{CC} = 3.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 4.5\text{нс}$	SOT353, SC88A	n.c. •INA•GND•OUTY•VCC
VC	MC74VHC1GT14DT	ON	Schminv	$V_{CC} = 3.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 4.5\text{нс}$	SOT23-5	n.c. •INA•GND•OUTY•VCC
VD	MC74VHC1G132DF	ON	SchmNAND	$V_{CC} = 2.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.6\text{нс}$	SOT353, SC88A	INB•INA•GND•OUTY•VCC
VD	MC74VHC1G132DT	ON	SchmNAND	$V_{CC} = 2.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.6\text{нс}$	SOT23-5	INB•INA•GND•OUTY•VCC
VT	MC74VHC1GT08DF	ON	2-AND	$V_{CC} = 3.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.5\text{нс}$	SOT353, SC88A	INB•INA•GND•OUTY•VCC
VT	MC74VHC1GT08DT	ON	2-AND	$V_{CC} = 3.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.5\text{нс}$	SOT23-5	INB•INA•GND•OUTY•VCC
VU	MC74VHC1GT132DF	MOT	SchmNAND	$V_{CC} = 3.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.6\text{нс}$	SOT353, SC88A	INB•INA•GND•OUTY•VCC
VU	MC74VHC1GT132DT	MOT	SchmNAND	$V_{CC} = 3.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.6\text{нс}$	SOT23-5	INB•INA•GND•OUTY•VCC
VX	MC74VHC1G09DF	ON	2-AND	$V_{CC} = 2.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 4.3\text{нс}$	SOT353, SC88A	INB•INA•GND•OUTY•VCC
VZ	MC74VHC1G135DF	ON	SchmNAND	$V_{CC} = 2.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 4.9\text{нс}$	SOT353, SC88A	INB•INA•GND•OUTY•VCC
VZ	MC74VHC1G135DT	ON	SchmNAND	$V_{CC} = 2.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 4.9\text{нс}$	SOT23-5	INB•INA•GND•OUTY•VCC
W0	MC74VHC1G125DF	ON	3-stbuff	$V_{CC} = 2.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.5\text{нс}$	SOT353, SC88A	OE•INA•GND•OUTY•VCC
W0	MC74VHC1G125DT	ON	3-stbuff	$V_{CC} = 2.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.5\text{нс}$	SOT23-5	OE•INA•GND•OUTY•VCC
W1	FMW1	ROHM	nnpn x2	$V_{CBO} = 60\text{В}$; $I_C = 150\text{мА}$; $P_D = 300\text{мВт}$; $\eta_{21} > 120$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
W1	MC74VHC1GT125DF	ON	3-stbuff	$V_{CC} = 3.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.5\text{нс}$	SOT353, SC88A	OE•INA•GND•OUTY•VCC
W1	MC74VHC1GT125DT	ON	3-stbuff	$V_{CC} = 3.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.5\text{нс}$	SOT23-5	OE•INA•GND•OUTY•VCC
W1	UMW1N	ROHM	nnpn x2	$V_{CBO} = 50\text{В}$; $I_C = 100\text{мА}$; P_D (com.) = 300мВт; $\eta_{21} = 180...560$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
W11	UMW11N	ROHM	nnpn x2	$V_{CBO} = 30\text{В}$; $I_C = 50\text{мА}$; P_D (com.) = 300мВт; $\eta_{21} = 27...270$; $f_T > 1500\text{МГц}$	SOT353, SC88A	E1•B1, B2•E2•C2•C1
W12	UMW12N	ROHM	nnpn x2	$V_{CBO} = 50\text{В}$; $I_C = 100\text{мА}$; P_D (com.) = 300мВт; $\eta_{21} > 120$	SOT353, SC88A	E1, C2•C1•B1•B2•E2
W13	UMW13N	ROHM	nnpn x2	$V_{CBO} = 30\text{В}$; $I_C = 50\text{мА}$; P_D (com.) = 300мВт; $\eta_{21} = 27...270$; $f_T > 2000\text{МГц}$	SOT353, SC88A	E1•B1, B2•E2•C2•C1
W2	FMW2	ROHM	nnpn x2	$V_{CBO} = 60\text{В}$; $I_C = 150\text{мА}$; $P_D = 300\text{мВт}$; $\eta_{21} > 120$	SOT23-5	C1•C2•E2•B1, B2•E1
W2	MC74VHC1G126DF	ON	3-stbuff	$V_{CC} = 2.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.5\text{нс}$	SOT353, SC88A	OE•INA•GND•OUTY•VCC
W2	MC74VHC1G126DT	ON	3-stbuff	$V_{CC} = 2.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.5\text{нс}$	SOT23-5	OE•INA•GND•OUTY•VCC
W2	UMW2N	ROHM	nnpn x2	$V_{CBO} = 50\text{В}$; $I_C = 100\text{мА}$; P_D (com.) = 300мВт; $\eta_{21} > 120$	SOT353, SC88A	E1•B1, B2•E2•C2•C1
W3	FMW3	ROHM	nnpn x2	$V_{CBO} = 120\text{В}$; $I_C = 50\text{мА}$; $P_D = 300\text{мВт}$; $\eta_{21} > 180$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
W3	MC74VHC1GT126DF	ON	3-stbuff	$V_{CC} = 3.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.5\text{нс}$	SOT353, SC88A	OE•INA•GND•OUTY•VCC
W3	MC74VHC1GT126DT	ON	3-stbuff	$V_{CC} = 3.0...5.5\text{В}$; $t_{prop} = 3.5\text{нс}$	SOT23-5	OE•INA•GND•OUTY•VCC
W4	FMW4	ROHM	nnpn x2	$V_{CBO} = 120\text{В}$; $I_C = 50\text{мА}$; $P_D = 300\text{мВт}$; $\eta_{21} > 180$	SOT23-5	C1•C2•E2•B1, B2•E1



SOT23-5 **SOT353**
TSOT23-5 **SC88A**



SOT553

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
W5	UMW5N	ROHM	npn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D(\text{com.})=300\text{ мВт}; h_{21}>250$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
W6	FMW6	ROHM	npn x2	$V_{CB0}=30\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>27$	SOT23-5	C2, E1•C1•B1•B2•E2
W6	UMW6N	ROHM	npn x2	$V_{CB0}=30\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D(\text{com.})=300\text{ мВт}; h_{21}=27...270; f_T>1500\text{ МГц}$	SOT353, SC88A	E2•B2•B1•C1•E1, C2
W7	FMW7	ROHM	npn x2	$V_{CB0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>27$	SOT23-5	C1, E2•C2•B2•B1•E1
W7	UMW7N	ROHM	npn x2	$V_{CB0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D(\text{com.})=300\text{ мВт}; h_{21}=27...270; f_T>3200\text{ МГц}$	SOT353, SC88A	E2•B2•B1•C1•E1, C2
W8	UMW8N	ROHM	npn x2	$V_{CB0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D(\text{com.})=300\text{ мВт}; h_{21}=27...270; f_T>3200\text{ МГц}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
W9	UMW9T	ROHM	npn x2	$V_{CB0}=20\text{ В}; I_C=50\text{ мА}; P_D(\text{com.})=300\text{ мВт}; h_{21}=27...270; f_T>3200\text{ МГц}$	SOT353, SC88A	E1•B1, B2•E2•C2•C1
XA	RN1501	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=4,7\text{ к}\Omega/4,7\text{ к}\Omega$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XA	RN1701	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=4,7\text{ к}\Omega/4,7\text{ к}\Omega$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XA	RN1701JE	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=4,7\text{ к}\Omega/4,7\text{ к}\Omega$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XB	RN1502	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=10\text{ к}\Omega/10\text{ к}\Omega$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XB	RN1702	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=10\text{ к}\Omega/10\text{ к}\Omega$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XB	RN1702JE	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=10\text{ к}\Omega/10\text{ к}\Omega$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XC	RN1503	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=22\text{ к}\Omega/22\text{ к}\Omega$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XC	RN1703	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=22\text{ к}\Omega/22\text{ к}\Omega$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XC	RN1703JE	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=22\text{ к}\Omega/22\text{ к}\Omega$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XD	RN1504	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=47\text{ к}\Omega/47\text{ к}\Omega$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XD	RN1704	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=47\text{ к}\Omega/47\text{ к}\Omega$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XD	RN1704JE	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=47\text{ к}\Omega/47\text{ к}\Omega$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XE	RN1505	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=2,2\text{ к}\Omega/47\text{ к}\Omega$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XE	RN1705	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=2,2\text{ к}\Omega/47\text{ к}\Omega$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XE	RN1705JE	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=2,2\text{ к}\Omega/47\text{ к}\Omega$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XF	RN1506	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=4,7\text{ к}\Omega/47\text{ к}\Omega$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XF	RN1706	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=4,7\text{ к}\Omega/47\text{ к}\Omega$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XF	RN1706JE	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=4,7\text{ к}\Omega/47\text{ к}\Omega$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XH	RN1507	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=10\text{ к}\Omega/47\text{ к}\Omega$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XH	RN1707	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=10\text{ к}\Omega/47\text{ к}\Omega$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XH	RN1707JE	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=100\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=10\text{ к}\Omega/47\text{ к}\Omega$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XI	RN1508	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=22\text{ к}\Omega/47\text{ к}\Omega$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XI	RN1708	TOSH	Dnpn x2	$V_{CB0}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; f_T=250\text{ МГц}; R_1/R_2=22\text{ к}\Omega/47\text{ к}\Omega$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1

SOT553

SOT353
SC88ASOT23-5
TSOT23-5

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
XI	RN1708JE	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт};$ $f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 22 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XJ	RN1509	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт};$ $f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 47 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XJ	RN1709	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт};$ $f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 47 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XJ	RN1709JE	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт};$ $f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 47 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XK	RN1510	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт};$ $f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} = 4.7 \text{ кОм}$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XK	RN1710	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт};$ $f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} = 4.7 \text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XK	RN1710JE	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт};$ $f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} = 4.7 \text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XM	RN1511	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт};$ $f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} = 10 \text{ кОм}$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XM	RN1711	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт};$ $f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} = 10 \text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
XM	RN1711JE	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт};$ $f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta 1} = 10 \text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
Y1	EMY1	ROHM	nnp+npn	$V_{CB0} = 60 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
Y1	FMY1A	ROHM	nnp+npn	$V_{CB0} = 60 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B1
Y1	UMY1N	ROHM	npn(1)+npn (2)	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D (\text{com.}) = 300 \text{ мВт};$ $h_{21} > 120; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
Y3	FMY3A	ROHM	nnp+npn	$V_{CB0} = 60 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT23-5	C1•C2•E2•B2, E1•B1
Y3	UMY3N	ROHM	npn(1)+npn (2)	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D (\text{com.}) = 300 \text{ мВт};$ $h_{21} = 120...560; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT353, SC88A	B1•E1, B2•E2•C2•C1
Y4	FMY4A	ROHM	nnp+npn	$V_{CB0} = 60 \text{ В}; I_C = 150 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT23-5	C1•C2•B2•B1, E2•E1
Y4	UMY4N	ROHM	npn(1)+npn (2)	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D (\text{com.}) = 300 \text{ мВт};$ $h_{21} = 120...560; f_T > 180 \text{ МГц}$	SOT353, SC88A	E1•B1, E2•B2•C2•C1
Y5	FMY5	ROHM	nnp+npn	$V_{CB0} = 120 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B2
Y6	FMY6	ROHM	nnp+npn	$V_{CB0} = 40 \text{ В}; I_C = 500 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT23-5	C1•C2•B2•E1, E2•B2
YA	RN2501	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YA	RN2701	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YA	RN2701JE	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YB	RN2502	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 10 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YB	RN2702	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 10 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YB	RN2702JE	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 10 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YC	RN2503	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 22 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YC	RN2703	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 22 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YC	RN2703JE	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 22 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YD	RN2504	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 47 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YD	RN2704	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 47 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YD	RN2704JE	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 47 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YE	RN2505	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta 1}/R_{\theta 2} = 2.2 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1



SOT23-5 **SC88A**
TSOT23-5



SOT553

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5
YE	RN2705	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f/R_2 = 2.2 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YE	RN2705JE	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f/R_2 = 2.2 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YF	RN2506	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f/R_2 = 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YF	RN2706	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f/R_2 = 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YF	RN2706JE	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f/R_2 = 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YH	RN2507	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f/R_2 = 10 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YH	RN2707	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f/R_2 = 10 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YH	RN2707JE	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f/R_2 = 10 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YI	RN2508	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f/R_2 = 22 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YI	RN2708	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f/R_2 = 22 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YI	RN2708JE	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f/R_2 = 22 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YJ	RN2509	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f/R_2 = 47 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YJ	RN2709	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f/R_2 = 47 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YJ	RN2709JE	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f/R_2 = 47 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YK	RN2510	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f = 4.7 \text{ кОм}$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YK	RN2710	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f = 4.7 \text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YK	RN2710JE	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f = 4.7 \text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YM	RN2511	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f = 10 \text{ кОм}$	SOT23-5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YM	RN2711	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f = 10 \text{ кОм}$	SOT353, SC88A	B1•E1, E2•B2•C2•C1
YM	RN2711JE	TOSH	Дрnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт};$ $f_T = 200 \text{ МГц}; R_f = 10 \text{ кОм}$	SOT553, EMT5	B1•E1, E2•B2•C2•C1
Z25	NC7SZ125P5X	FAIR	3-stbuff	$V_{CC} = 1.65 \dots 5.5 \text{ В}; I_{OUT} = \pm 24 \text{ мА}$	SOT353, SC88A	OE•A•GND•Y•VCC

fS6 SON-6 SOT563
M16 USM-6 SOT666SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6

SOT23-6, SOT363/563...

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
11	MUN5311DW1	ON	Dnprn/pnp	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 35$; 10 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
12	MUN5312DW1	ON	Dnprn/pnp	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 60$; 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
13	MUN5313DW1	ON	Dnprn/pnp	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 80$; 47 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
14	MUN5314DW1	ON	Dnprn/pnp	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 80$; 10 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
15	MUN5315DW1	ON	Dnprn/pnp	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 160$; R ₁ 10 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
16	MUN5316DW1	ON	Dnprn/pnp	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 160$; R ₁ 4,7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
30	MUN5330DW1	ON	Dnprn/pnp	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 3$; 1 кОм/1 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
31	MUN5331DW1	ON	Dnprn/pnp	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 8$; 2,2 кОм/2,2 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
32	MUN5332DW1	ON	Dnprn/pnp	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 15$; 4,7 кОм/4,7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
33	MUN5333DW1	ON	Dnprn/pnp	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 80$; 4,7 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
34	MUN5334DW1	ON	Dnprn/pnp	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 80$; 22 кОм/4,7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
35	MUN5335DW1	ON	Dnprn/pnp	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 80$; 2,2 кОм/4,7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
#CHA	AD7414ARTZ	AD	dts	10-паэр.; SMBus/I ² C; V _{DD} =2.7...5.5 В	SOT23-6	AS•GND•VDD•SCL•ALERT•SDA
0A	NSBA114EDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 357$ мВт; $h_{21} > 35$; 10 кОм/10 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0A	MUN5111DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 35$; 10 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0B	NSBA124EDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 357$ мВт; $h_{21} > 60$; 22 кОм/22 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0B	MUN5112DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 60$; 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0C	NSBA144EDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 357$ мВт; $h_{21} > 80$; 47 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0C	MUN5113DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 80$; 47 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0D	NSBA114YDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 357$ мВт; $h_{21} > 80$; 10 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0D	MUN5114DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 80$; 10 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0E	NSBA114TDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 357$ мВт; $h_{21} > 160$; R ₁ 10 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0E	MUN5115DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 160$; R ₁ 10 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0F	NSBA143TDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 357$ мВт; $h_{21} > 160$; R ₁ 4,7 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0F	MUN5116DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 160$; R ₁ 4,7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0G	MUN5130DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 200$ мВт; $h_{21} > 3$; 1 кОм/1 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0G	NSBA113EDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D0} = 50$ В; $I_C = 100$ мА; $P_D = 357$ мВт; $h_{21} > 3$; 1 кОм/1 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
0H	NSBA123EDXV6	ON	Dnpnp x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 357\text{ мВт}; h_{21} > 8;$ 2,2 кОм/2,2 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0H	MUN5131DW1	ON	Dnpnp x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 8;$ 2,2 кОм/2,2 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0J	NSBA143EDXV6	ON	Dnpnp x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 357\text{ мВт}; h_{21} > 15;$ 4,7 кОм/4,7 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0J	MUN5132DW1	ON	Dnpnp x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 15;$ 4,7 кОм/4,7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0K	NSBA1432DXV6	ON	Dnpnp x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 357\text{ мВт}; h_{21} > 80;$ 4,7 кОм/4,7 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0K	MUN5133DW1	ON	Dnpnp x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 80;$ 4,7 кОм/4,7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0L	NSBA124DXV6	ON	Dnpnp x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 357\text{ мВт}; h_{21} > 80;$ 22 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0L	MUN5134DW1	ON	Dnpnp x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 80;$ 22 кОм/4,7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0M	NSBA123JDXV6	ON	Dnpnp x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 357\text{ мВт}; h_{21} > 80;$ 2,2 кОм/4,7 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0M	MUN5135DW1	ON	Dnpnp x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 80;$ 2,2 кОм/4,7 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0N	MUN5136DW1	ON	Dnpnp x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 80;$ 100 кОм/100 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0N	NSBA115EDXV6	ON	Dnpnp x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 357\text{ мВт}; h_{21} > 80;$ 100 кОм/100 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0P	MUN5137DW1	ON	Dnpnp x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 80;$ 47 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
0P	NSBA144WDXV6	ON	Dnpnp x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 357\text{ мВт}; h_{21} > 80;$ 47 кОм/22 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
100	NMT2222	NS	nnp	$V_{CEB} = 75\text{ В}; I_C = 1\text{ А}; h_{21} > 35; f_t > 300\text{ МГц}$	SOT23-6	B1•E2•B2•C2•E1•C1
1000	ZXTS1000E6	ZETEX	pnp+shd	$V_{CEO} = 12\text{ В}; I_C = 1,25\text{ А}; V_R = 40\text{ В}; I_E = 0,5\text{ А}$	SOT23-6	C•E•K•A•n. c. •B1
11	NSBC114EPDXV6	ON	Dnpnp/pnp	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 357\text{ мВт}; h_{21} > 35;$ 10 кОм/10 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
11	RN46A1	TOSH	Dnpnp/nnp	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт};$ Q1: $R_1/R_2 = 22\text{ кОм}/22\text{ кОм};$ Q2: $R_1/R_2 = 10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
12	NSBC124EPDXV6	ON	Dnpnp/pnp	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 357\text{ мВт}; h_{21} > 60;$ 22 кОм/22 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
13	NSBC144EPDXV6	ON	Dnpnp/pnp	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 357\text{ мВт}; h_{21} > 80;$ 47 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
14	NSBC114YPDXV6	ON	Dnpnp/pnp	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 357\text{ мВт}; h_{21} > 80;$ 10 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
15	NSBC114TPDXV6	ON	Dnpnp/pnp	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 357\text{ мВт}; h_{21} > 160;$ $R_1 10\text{ кОм}$	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
15	RN49A1	TOSH	Dnpnp/nnp	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт};$ Q1: $R_1/R_2 = 2,2\text{ кОм}/47\text{ кОм};$ Q2: $R_1/R_2 = 22\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
16	MT6L61AFS	TOSH	nnp x2	$V_{CEB} = 5\text{ В}; I_C = 25/40\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт}; f_t > 7\text{ ГГц}$	fS6	B2•E2•B1•C1•E1•C2
16	NSBC143TPDXV6	ON	Dnpnp/pnp	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 357\text{ мВт}; h_{21} > 160;$ $R_1 4,7\text{ кОм}$	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
17	MT6L62AFS	TOSH	nnp x2	$V_{CEB} = 5\text{ В}; I_C = 25/40\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт}; f_t > 10\text{ ГГц}$	fS6	B2•E2•B1•C1•E1•C2
17B	RN4962FE	TOSH	Dnpnp/nnp	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_t = 200\text{ МГц};$ $R_1/R_2 = 10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
1Bs	BC817JPN	INF	nnp/pnp	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 330\text{ мВт};$ $h_{21} = 160...400; f_t = 170\text{ МГц}$	SOT457, SC74	E1•B1•C2•E2•B2•C1
1Cs	BC847S	INF	nnp x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт};$ $h_{21} = 110...630; f_t = 250\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
1Ds	BC846U	INF	nnp x2	$V_{CEB} = 80\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт};$ $h_{21} = 200...450; f_t = 250\text{ МГц}$	SOT457, SC74	E1•B1•C2•E2•B2•C1

f56 SON-6
M16 USM-6

SOT563
SOT666



SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
10s	BC846PN	INF	npn/npn	$V_{CE0} = 80 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 250 мВт$; $h_{21} = 200...450$; $f_T > 100 МГц$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
1Ps	BC847PN	INF	npn/npn	$V_{CE0} = 50 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 250 мВт$; $h_{21} = 110...630$; $f_T = 250 МГц$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
24R	μPA810T	NEC	npn x2	$V_{CE0} = 20 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 230 мВт$; $h_{21} = 70...140$; $f_T > 3 ГГц$	SOT363, SC88	C1•E1•C2•E2•B2•B1
25R	μPA810T	NEC	npn x2	$V_{CE0} = 20 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 230 мВт$; $h_{21} = 110...240$; $f_T > 3 ГГц$	SOT363, SC88	C1•E1•C2•E2•B2•B1
28	RN49A2	TOSH	Dnpn/npn	$V_{CE0} = 50 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 200 мВт$; Q1: $R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм$; Q2: $R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
2N02	ZXM62N02E6	ZETEX	nMOS	$V_{DS} = 20 В$; $I_D = 2.6 А$; $P_D = 330 мВт$; $R_{DS(on)} < 0.125 Ом$	SOT23-6	D•D•G•S•D•D
30	NSBC113EPDXV6	ON	Dnpn/npn	$V_{CE0} = 50 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 357 мВт$; $h_{21} > 3$; 1 кОм/1 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
31	NSBC123EPDXV6	ON	Dnpn/npn	$V_{CE0} = 50 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 357 мВт$; $h_{21} > 8$; 2.2 кОм/2.2 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
32	NSBC143EPDXV6	ON	Dnpn/npn	$V_{CE0} = 50 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 357 мВт$; $h_{21} > 15$; 4.7 кОм/4.7 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
33	NSBC143PDXV6	ON	Dnpn/npn	$V_{CE0} = 50 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 357 мВт$; $h_{21} > 80$; 4.7 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
34	NSBC124PDXV6	ON	Dnpn/npn	$V_{CE0} = 50 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 357 мВт$; $h_{21} > 80$; 22 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
34R	μPA8121FB	NEC	npn x2	$V_{CE0} = 20 В$; $I_C = 65 мА$; $P_D = 200 мВт$; $h_{21} = 70...150$; $f_T > 4.5 ГГц$	SOT363, SC88	C1•B2•C2•E2•E1•B1
35	NSBC1231PDXV6	ON	Dnpn/npn	$V_{CE0} = 50 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 357 мВт$; $h_{21} > 80$; 2.2 кОм/4.7 кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
35R	μPA8121TGB	NEC	npn x2	$V_{CE0} = 20 В$; $I_C = 65 мА$; $P_D = 200 мВт$; $h_{21} = 110...240$; $f_T > 4.5 ГГц$	SOT363, SC88	C1•B2•C2•E2•E1•B1
3Cs	BC857S	INF	npn x2	$V_{CE0} = 50 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 250 мВт$; $h_{21} = 125...630$; $f_T = 250 МГц$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
3F	μPA873TC	NEC	npn x2	$V_{CE0} = 9 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 230 мВт$; $h_{21} = 100...145$; $f_T > 3 ГГц$	USM-6	C1•E1•C2•E2•B2•B1
3Ft	BC857BS	PHIL	npn x2	$V_{CE0} = 50 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 330 мВт$; $h_{21} = 220...475$; $f_T > 150 МГц$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
3G	MGSF3454X	ON	nMOS	$I_D = 1.75 А$	SOT457, SC74	D•D•G•S•D•D
44R	μPA8111FB	NEC	npn x2	$V_{CE0} = 20 В$; $I_C = 35 мА$; $P_D = 200 мВт$; $h_{21} = 80...160$; $f_T > 5.5 ГГц$	SOT363, SC88	C1•B2•C2•E2•E1•B1
4591	ZXTD4591E6	ZETEX	npn/npn	$V_{CE0} = 80 В$; $I_C = 1 А$; $h_{21} > 20$; $P_D = 1.1 Вт$	SOT23-6	C1•B1•C2•E2•B2•E1
45R	μPA8111TGB	NEC	npn x2	$V_{CE0} = 20 В$; $I_C = 35 мА$; $P_D = 200 мВт$; $h_{21} = 125...250$; $f_T > 5.5 ГГц$	SOT363, SC88	C1•B2•C2•E2•E1•B1
46	MBT3946DW1	ON	npn/npn	$V_{CE0} = 40 В$; $I_C = 200 мА$; $P_D = 150 мВт$; $h_{21} > 30$; $f_T > 250 МГц$	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
4B	μPA891TC	NEC	npn x2	$V_{CE0} = 9 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 230 мВт$; $h_{21} = 100...160$; $f_T > 3.5 ГГц$	USM-6	C1•E1•C2•B2•E2•B1
4C	μPA892TC	NEC	npn x2	$V_{CE0} = 15 В$; $I_C = 35 мА$; $P_D = 210 мВт$; $h_{21} = 50...100$; $f_T > 18 ГГц$	USM-6	C1•E1•C2•B2•E2•B1
5Ft	BC856S	PHIL	npn x2	$V_{CE0} = 80 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 200 мВт$; $h_{21} > 110$; $f_T > 100 МГц$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
62s	BAT62-08S	INF	shd x3	$V_R < 40 В$; $I_R < 20 мА$; $V_F (I_F = 2 мА) < 1 В$; $I_R < 10 мкА$; $C_D < 0.6 нФ$	SOT363, SC88	A1•A2•A3•K3•K2•K1
69s	BAT62-09S	INF	shd x2	$V_R < 40 В$; $I_R < 20 мА$; $V_F (I_F = 2 мА) < 1 В$; $I_R < 10 мкА$; $C_D < 0.6 нФ$	SOT363, SC88	A1•n.c. •A2•K2•n.c. •K1
6A	RN4981	TOSH	Dnpn/npn	$V_{CE0} = 50 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 200 мВт$; $f_T = 200 МГц$; $R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6A	RN4981FE	TOSH	Dnpn/npn	$V_{CE0} = 50 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 100 мВт$; $f_T = 200 МГц$; $R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
6B	RN4982	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6B	RN4982FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6C	RN4983	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 22\text{ кОм}/22\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6C	RN4983FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 22\text{ кОм}/22\text{ кОм}$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6D	RN4984	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 47\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6D	RN4984FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 47\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6E	RN4985	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 2.2\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6E	RN4985FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 2.2\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6F	RN4986	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 4.7\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6F	RN4986FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 4.7\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6H	RN4987	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 10\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6H	RN4987FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 10\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6I	RN4988	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 22\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6I	RN4988FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 22\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6J	RN4989	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 47\text{ кОм}/22\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6J	RN4989FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1/R_2 = 47\text{ кОм}/22\text{ кОм}$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6K	RN4990	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1 = 4.7\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6K	RN4990FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1 = 4.7\text{ кОм}$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6M	RN4991	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1 = 10\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
6M	RN4991FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1 = 10\text{ кОм}$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
70	μPA801TCFB	NEC	nnpn x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 230\text{ мВт}; h_{21} = 70...140; f_T > 3\text{ ГГц}$	USM-6	C1•E1•C2•E2•B2•B1
71	μPA801TCGB	NEC	nnpn x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 230\text{ мВт}; h_{21} = 125...250; f_T > 3\text{ ГГц}$	USM-6	C1•E1•C2•E2•B2•B1
72	μPA804TCFB	NEC	nnpn x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 60\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 60...120; f_T > 3\text{ ГГц}$	USM-6	C1•E1•C2•E2•B2•B1
73	μPA804TCGB	NEC	nnpn x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 60\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} = 100...200; f_T > 3\text{ ГГц}$	USM-6	C1•E1•C2•E2•B2•B1
73T	μPA813TFB	NEC	nnpn x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 30\text{ мА}; P_D = 160\text{ мВт}; h_{21} = 60...120; f_T = 5.5\text{ ГГц}$	SOT363, SC88	C1•B2•C2•E2•E1•B1
74s	BAS70-04S	INF	shd x4	$V_C < 70\text{ В}; I_C < 70\text{ мА}; V_C (I_C = 15\text{ мА}) < 1.0\text{ В}; I_C < 0.1\text{ мА}; C_C < 2.0\text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1•K2•A3, K4•A4•K3•K1, A2
74T	μPA813TGB	NEC	nnpn x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 30\text{ мА}; P_D = 160\text{ мВт}; h_{21} = 100...200; f_T = 5.5\text{ ГГц}$	SOT363, SC88	C1•B2•C2•E2•E1•B1
75	μPA810TC	NEC	nnpn x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 230\text{ мВт}; h_{21} = 70...140; f_T > 3\text{ ГГц}$	USM-6	C1•E1•C2•E2•B2•B1
7A	MUN5211DW1	ON	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 35; 10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2

fS6 SON-6
M16 USM-6SOT563
SOT666SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
7A	NSBC114EDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=357\text{ мВт}; h_{21}>35;$ 10кОм/10кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7B	MUN5212DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>60;$ 22кОм/22кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7B	NSBC124EDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=357\text{ мВт}; h_{21}>60;$ 22кОм/22кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7C	MUN5213DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>80;$ 47кОм/47кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7C	NSBC144EDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=357\text{ мВт}; h_{21}>80;$ 47кОм/47кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7D	MUN5214DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>80;$ 10кОм/47кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7D	NSBC114YDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=357\text{ мВт}; h_{21}>80;$ 10кОм/47кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7E	MUN5215DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>160;$ $R_1=10\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7E	NSBC114TDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=357\text{ мВт}; h_{21}>160;$ $R_1=10\text{ кОм}$	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7F	MUN5216DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>160;$ $R_1=4.7\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7F	NSBC143TDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=357\text{ мВт}; h_{21}>160;$ $R_1=4.7\text{ кОм}$	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7G	MUN5230DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>3;$ 1кОм/1кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7G	NSBC113EDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=357\text{ мВт}; h_{21}>3;$ 1кОм/1кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7H	MUN5231DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>8;$ 2.2кОм/2.2кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7H	NSBC123EDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=357\text{ мВт}; h_{21}>8;$ 2.2кОм/2.2кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7J	MUN5232DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>15;$ 4.7кОм/4.7кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7J	NSBC143EDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=357\text{ мВт}; h_{21}>15;$ 4.7кОм/4.7кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7K	MUN5233DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>80;$ 4.7кОм/47кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7K	NSBC143ZDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=357\text{ мВт}; h_{21}>80;$ 4.7кОм/47кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7L	MUN5234DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>80;$ 22кОм/4.7кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7L	NSBC124DXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=357\text{ мВт}; h_{21}>80;$ 22кОм/47кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7M	MUN5235DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>80;$ 2.2кОм/4.7кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7M	NSBC123JDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=357\text{ мВт}; h_{21}>80;$ 2.2кОм/4.7кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7N	MUN5236DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>80;$ 100кОм/100кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7N	NSBC115EDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=357\text{ мВт}; h_{21}>80;$ 100кОм/100кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7P	MUN5237DW1	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=200\text{ мВт}; h_{21}>80;$ 47кОм/22кОм	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
7P	NSBC144WDXV6	ON	Dnprn x2	$V_{D90}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=357\text{ мВт}; h_{21}>80;$ 47кОм/22кОм	SOT563, EMT6	E2•B2•C1•E1•B1•C2
83s	BAT68-08S	INF	shd x3	$V_A < 8\text{ В}; I_C < 130\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 0.5\text{ В};$ $I_S < 0.1\text{ мА}; C_D < 1.0\text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1•A2•A3•K3•K2•K1
87	μPA814TC	NEC	npn x2	$V_{D90}=9\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; P_D=230\text{ мВт}; h_{21}=80...160;$ $f_T > 4\text{ ГГц}$	USM-6	C1•B2•C2•E2•E1•B1



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
88T	μP814T	NEC	pnп x2	$V_{CC} = 9\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 230\text{ мВт}; h_{21} = 80...160;$ $f_T > 4\text{ ГГц}$	SOT363, SC88	C1•B2•C2•E2•E1•B1
89s	BAT68-09S	INF	shd x2	$V_R < 8\text{ В}; I_R < 130\text{ мА}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 0.5\text{ В};$ $I_R < 0.1\text{ мкА}; C_D < 1.0\text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1•п.с.•A2•K2•п.с.•K1
A1s	BAW56S	INF	di x4	$V_R < 80\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 150\text{ мА}) < 1.25\text{ В};$ $C_D < 2.0\text{ нФ}; t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOT363, SC88	K1•K2•A3, A4•K4•K3•A2, A1
A1s	BAW56U	INF	di x4	$V_R < 80\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 150\text{ мА}) < 1.25\text{ В};$ $C_D < 2.0\text{ нФ}; t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOT457, SC74	K1•K2•A3, A4•K4•K3•A2, A1
A1t	BAW56S	PHIL	di x2	$V_R < 85\text{ В}; I_R < 250\text{ мА}; V_F (I_F = 50\text{ мА}) < 1\text{ В};$ $I_R < 1\text{ мкА}; C_D < 2.0\text{ нФ}; t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOT363, SC88	K1•K2•A3, A4•K4•K3•A2, A1
A2	MBT3906DW1	ON	pnп x2	$V_{CC} = 40\text{ В}; I_C = 200\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 30;$ $f_T > 250\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E2•B2•C1•E1•B1•C2
A40	OPA363I	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 1.8...5.5\text{ В}; I_{DD} = 7\text{ мА}; I_S = 1.4\text{ мА};$ $V_{OS} < 0.9\text{ мВ}$	SOT23-6	OUT•V-•+IN•-IN•ENBL•V+
A4s	BAV70S	INF	di x4	$V_R < 80\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 50\text{ мА}) < 1\text{ В};$ $I_R (V_R = 70\text{ В}) < 0.15\text{ мкА}; C_D < 1.5\text{ нФ}; t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOT363, SC88	A1•A2•K3, K4•A4•A3•K1, K2
A4s	BAV70U	INF	di x4	$V_R < 80\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 50\text{ мА}) < 1\text{ В};$ $I_R (V_R = 70\text{ В}) < 0.15\text{ мкА}; C_D < 1.5\text{ нФ}; t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOT457, SC74	A1•A2•K3, K4•A4•A3•K1, K2
A5	HN2D02FU	TOSH	di x3	$V_R < 80\text{ В}; I_R < 80\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 1.2\text{ В};$ $C_D < 4\text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1•A2•A3•K3•K2•K1
A6	HN2S01F	TOSH	shd x3	$V_R < 10\text{ В}; I_R < 100\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 0.5\text{ В};$ $C_D < 40\text{ нФ}$	SOT23-6	K1•K2•K3•A3•A2•A1
A6	HN2S01FU	TOSH	shd x3	$V_R < 10\text{ В}; I_R < 100\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 0.5\text{ В};$ $C_D < 40\text{ нФ}$	SOT363, SC88	K1•K2•K3•A3•A2•A1
A6s	BAS16S	INF	di x3	$V_R < 80\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 150\text{ мА}) < 1.25\text{ В};$ $I_R < 50\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•A2•A3•K3•K2•K1
A6s	BAS16U	INF	di x3	$V_R < 80\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 150\text{ мА}) < 1.25\text{ В};$ $I_R < 50\text{ мкА}$	SOT457, SC74	A1•A2•A3•K3•K2•K1
A7s	BAV99S	INF	di x4	$V_R < 80\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 150\text{ мА}) < 1.25\text{ В};$ $I_R < 0.15\text{ мкА}; C_D < 1.5\text{ нФ}; t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOT363, SC88	A1•K2•A3, K4•A4•K3•A2, K1
A7s	BAV99U	INF	di x4	$V_R < 80\text{ В}; I_R < 200\text{ мА}; V_F (I_F = 150\text{ мА}) < 1.25\text{ В};$ $I_R < 0.15\text{ мкА}; C_D < 1.5\text{ нФ}; t_{RR} < 4\text{ нс}$	SOT457, SC74	A1•K2•A3, K4•A4•K3•A2, K1
A8	HN2S03FU	TOSH	shd x3	$V_R < 20\text{ В}; I_R < 50\text{ мА}; V_F (I_F = 50\text{ мА}) < 0.55\text{ В};$ $C_D = 3.9\text{ нФ}$	SOT363, SC88	K1•K2•K3•A3•A2•A1
A9	HN2S02FU	TOSH	shd x3	$V_R < 40\text{ В}; I_R < 100\text{ мА}; V_F (I_F = 100\text{ мА}) < 0.6\text{ В};$ $C_D = 18\text{ нФ}$	SOT363, SC88	K1•K2•K3•A3•A2•A1
A9A	AD8591ART	AD	OA	$f_{BD} = 2.2\text{ МГц}; P_D = 7\text{ мВт}; V_{DD} = 2.5...6\text{ В}$	SOT23-6	OUT A•V-•+IN A•-IN A•SD•V+
AAA	MAX9010EXT	MAX	cmp	$V_{OS} < \pm 7\text{ мВ}; V_{CC} = 4.5...5.5\text{ В}; I_{CC} < 2.1\text{ мА}$	SOT363, SC88	OUT•GND•IN+•IN-•VCC•VCC
AAAA	MAX2633EUT	MAX	amp	$V_{CC} = 2.7...5.5\text{ В}; f_p < 900\text{ МГц}; I_{CC} = 6.6\text{ мА}$	SOT23-6	SHDN•GND•OUT•VCC•BIAS•IN
AAAA	MAX5161LEZT	MAX	Dpot	32 позиции; 50 кОм; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-6	L•H•GND•U/D•INC•VDD
AAAB	MAX4180EUT	MAX	OA	$V_{DD} = +5/\pm 2.25... \pm 5.5\text{ В}; f_{BD} = 270\text{ МГц};$ $V_{OS} < \pm 7\text{ мВ}$	SOT23-6	OUT•VEE•IN+•IN-•SHDN•VCC
AAAB	MAX5161MEZT	MAX	Dpot	32 позиции; 100 кОм; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-6	L•H•GND•U/D•INC•VDD
AAAC	MAX4181EUT	MAX	OA	$V_{DD} = +5/\pm 2.25... \pm 5.5\text{ В}; f_{BD} = 270\text{ МГц};$ $V_{OS} < \pm 7\text{ мВ}$	SOT23-6	OUT•VEE•IN+•IN-•SHDN•VCC
AAAC	MAX5161NEZT	MAX	Dpot	32 позиции; 200 кОм; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-6	L•H•GND•U/D•INC•VDD
AAAD	MAX4223EUT	MAX	OA	$V_{DD} = \pm 2.85... \pm 5.5\text{ В}; f_{BD} = 1\text{ ГГц}; V_{OS} < 7\text{ мВ}$	SOT23-6	OUT•VEE•IN+•IN-•SHDN•VCC
AAAE	MAX4224EUT	MAX	OA	$V_{DD} = \pm 2.85... \pm 5.5\text{ В}; f_{BD} = 1\text{ ГГц}; V_{OS} < 7\text{ мВ}$	SOT23-6	OUT•VEE•IN+•IN-•SHDN•VCC
AAAF	MAX2660EUT	MAX	upmixer	$V_{CC} = 2.7...5.5\text{ В}; f_p = 400...2500\text{ МГц}; I_{CC} = 4.8\text{ мА}$	SOT23-6	LO•GND•IFIN•RFOUT•VCC•SHDN
AAAG	MAX2661EUT	MAX	upmixer	$V_{CC} = 2.7...5.5\text{ В}; f_p = 400...2500\text{ МГц}; I_{CC} = 8.3\text{ мА}$	SOT23-6	LO•GND•IFIN•RFOUT•VCC•SHDN
AAAH	MAX2662EUT	MAX	upmixer	$V_{CC} = 2.7...5.5\text{ В}; f_p = 400...2500\text{ МГц}$	SOT23-6	LOIN•GND•IFIN•RFOUT•VCC•SHDN

f56 SON-6 SOT563 1 2 3 4 5 6
M16 USM-6 SOT666 3 4 5 6

SOT363 SOT457 SOT23-6 1 2 3 4 5 6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6 3 4 5 6

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4+5+6
AAAI	MAX5383EZT	MAX	DAC	8-разр.; SPI/OSPI/Microwire; $V_{DD}=2.7...3.6$ В; $V_{REF}=2$ В	TSOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AAAJ	MAX2671EUT	MAX	upmixer	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=400...2500$ МГц; $I_{CC}=11.8$ мА	SOT23-6	LO • GND • IFIN • RFOUT • VCC • SHDN
AAAJ	MAX5385EZT	MAX	DAC	8-разр.; SPI/OSPI/Microwire; $V_{DD}=2.7...5.5$ В; $V_{REF}=0.9 \times V_{DD}$	TSOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AAAL	MAX2663EUT	MAX	upmixer	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=400...2500$ МГц; $I_{CC}=3.0$ мА	SOT23-6	LO • GND • IFIN • RFOUT • VCC • SHDN
AAAM	MAX4544EUT	MAX	asw	SPDT; $R_{ON} < 75$ Ом; $V_{DD}=2.7...12$ В	SOT23-6	IN • V+ • GND • NC • COM • NO
AAAO	MAX998EUT	MAX	cmp	R-R; $V_{OS} \leq \pm 3$ мВ; $V_{CC}=2.7...5.5$ В; $I_{CC} < 650$ мкА	SOT23-6	OUT • GND • IN+ • IN- • SHDN • VCC
AAAQ	MAX4529UT	MAX	asw	двунапр. РЧ/видео; $R_{ON} < 100$ Ом; $V_{DD}=2.7...12/\pm 2.7...6$ В	SOT23-6	NC • V+ • V- • IN • GND • COM
AAAR	MAX2680EUT	MAX	dnmixer	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=400...2500$ МГц; $I_{CC} < 21.8$ мА	SOT23-6	LO • GND • RFIN • IFOUT • VCC • SHDN
AAAS	MAX2681EUT	MAX	dnmixer	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=400...2500$ МГц; $I_{CC} < 21.8$ мА	SOT23-6	LO • GND • RFIN • IFOUT • VCC • SHDN
AAAT	MAX2682EUT	MAX	dnmixer	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=400...2500$ МГц; $I_{CC} < 21.8$ мА	SOT23-6	LO • GND • RFIN • IFOUT • VCC • SHDN
AAAU	MAX6817EUT	MAX	swd x2	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-6	IN1 • GND • IN2 • OUT2 • VCC • OUT1
AAAV	MAX2640EUT	MAX	amp	SiGe; $V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=400...1500$ МГц; $I_{CC}=3.5$ мА	SOT23-6	RFIN • GND • GND • RFOUT • GND • VCC
AAAW	MAX2641EUT	MAX	amp	SiGe; $V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=1400...2500$ МГц; $I_{CC}=3.5$ мА	SOT23-6	RFIN • GND • GND • RFOUT • GND • VCC
AAAX	MAX2470EUT	MAX	amp	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=10...200/10...500$ МГц; $I_{CC} < 7.4$ мА	SOT23-6	OUT • GND • OUT • HI/LO (IN) • IN • VCC
AAAY	MAX2471EUT	MAX	amp	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=10...500$ МГц; $I_{CC} < 7.4$ мА	SOT23-6	OUT • GND • OUT • HI/LO (IN) • IN • VCC
AAAZ	MAX2472EUT	MAX	amp	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=500...2500$ МГц; $I_{CC} < 8$ мА	SOT23-6	OUT1 • GND • OUT2 • IN • GND • VCC
AAB	MAX4401AXT	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.5...5.5$ В; $f_{3dB}=800$ кГц; $V_{OS} < 5$ мВ	SOT363, SC88	IN+ • VSS • IN- • OUT • SHDN • VDD
AABA	MAX2473EUT	MAX	amp	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=500...2500$ МГц; $I_{CC}=2.7$ мА	SOT23-6	OUT • GND • BIAS • IN • GND • VCC
AABB	MAX2605EUT	MAX	VCO	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=45...70$ МГц; $I_{CC}=1.9$ мА	SOT23-6	IND • GND • TUNE • OUT • VCC • OUT+
AABC	MAX2606EUT	MAX	VCO	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=70...150$ МГц; $I_{CC}=2.1$ мА	SOT23-6	IND • GND • TUNE • OUT • VCC • OUT+
AABD	MAX2607EUT	MAX	VCO	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=150...300$ МГц; $I_{CC}=2.1$ мА	SOT23-6	IND • GND • TUNE • OUT • VCC • OUT+
AABE	MAX2608EUT	MAX	VCO	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=300...500$ МГц; $I_{CC}=2.7$ мА	SOT23-6	IND • GND • TUNE • OUT • VCC • OUT+
AABF	MAX2609EUT	MAX	VCO	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=500...650$ МГц; $I_{CC}=3.6$ мА	SOT23-6	IND • GND • TUNE • OUT • VCC • OUT+
AABG	MAX6575LZUT	MAX	dts	$T_{AMB}=-40...125$ °C; $V_{CC}=2.7...5.5$ В; $I_{CC} < 400$ мА	SOT23-6	VDD • GND • n. c. • TS0 • TS1 • I/O
AABH	MAX6575HZUT	MAX	dts	$T_{AMB}=-40...125$ °C; $V_{CC}=2.7...5.5$ В; $I_{CC} < 400$ мА	SOT23-6	VDD • GND • n. c. • TS0 • TS1 • I/O
AABI	MAX6576ZUT	MAX	dts	$T_{AMB}=-40...125$ °C; $V_{CC}=2.7...5.5$ В; $I_{CC} < 400$ мА	SOT23-6	VDD • GND • n. c. • TS0 • TS1 • OUT
AABJ	MAX6577ZUT	MAX	dts	$T_{AMB}=-40...125$ °C; $V_{CC}=2.7...5.5$ В; $I_{CC} < 400$ мА	SOT23-6	VDD • GND • n. c. • TS0 • TS1 • OUT
AABN	MAX4173TEUT	MAX	CSA	$V_{DD}=3...28$ В; $f_{3dB}=1.7$ МГц; Gain=20; $I_{CC} < 1$ мА	SOT23-6	GND • GND • VCC • RS+ • RS- • OUT
AABO	MAX4173FEUT	MAX	CSA	$V_{DD}=3...28$ В; $f_{3dB}=1.7$ МГц; Gain=50; $I_{CC} < 1$ мА	SOT23-6	GND • GND • VCC • RS+ • RS- • OUT
AABP	MAX4173HEUT	MAX	CSA	$V_{DD}=3...28$ В; $f_{3dB}=1.7$ МГц; Gain=100; $I_{CC} < 1$ мА	SOT23-6	GND • GND • VCC • RS+ • RS- • OUT
AABQ	MAX4285EUT	MAX	buf	$V_{DD}=+2.85...+6.5/\pm 1.425...+3.25$ В; $f_{3dB}=250$ МГц; $V_{OS} \leq \pm 12$ мВ	SOT23-6	OUT • VEE • IN+ • IN- • DISABLE • VCC
AABR	MAX4286EUT	MAX	buf	$V_{DD}=+2.85...+6.5/\pm 1.425...+3.25$ В; $f_{3dB}=150$ МГц; $V_{OS} \leq \pm 12$ мВ	SOT23-6	OUT • VEE • IN+ • IN- • DISABLE • VCC
AABV	MAX1697REUT	MAX	vcpcon	$V_{IN}=1.25...5.5$ В; $f_p=12$ кГц; $I_{OUT}=60$ мА	SOT23-6	OUT • IN • C1 • GND • SHDN • C1+
AABW	MAX1697SEUT	MAX	vcpcon	$V_{IN}=1.25...5.5$ В; $f_p=35$ кГц; $I_{OUT}=60$ мА	SOT23-6	OUT • IN • C1 • GND • SHDN • C1+



SOT23-6 **SOT457** **SOT363**
TSOT23-6 **MW-6** **TSOT363**



SOT563 **SON-6** **fS6**
SOT666 **USM-6** **M16**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AABX	MAX1697TEUT	MAX	всрcon	$V_{IN} = 1.25...5.5B$; $f_p = 125 \text{ кГц}$; $I_{OUT} = 60 \text{ мА}$	SOT23-6	OUT • IN • C1 • GND • SHDN • C1+
AABY	MAX1697UEUT	MAX	всрcon	$V_{IN} = 1.25...5.5B$; $f_p = 250 \text{ кГц}$; $I_{OUT} = 60 \text{ мА}$	SOT23-6	OUT • IN • C1 • GND • SHDN • C1+
AABZ	MAX4510EJ	MAX	asw	SPST; $R_{ON} < 225 \text{ МОм}$; $V_{DD} = 9...36/4.5...120 \text{ В}$	SOT23-6	V+ • V- • IN • GND • COM • NC
AAC	MAX2642EXT	MAX	amp	SiGe; $V_{CC} = 2.7...5.5B$; $f_p = 800...1000 \text{ МГц}$; $I_{CC} < 7.5 \text{ мА}$	SOT363, SC88	BIAS • GND • RFIN • VCC • GND • RFOUT
AACB	MAX6351LSUT	MAX	mrc	$V_{TR1} = 4.63B$; $V_{TR2} = 2.93B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 50 \text{ мкА}$	SOT23-6	RST1 • GND • MR • VCC2 • RST2 • VCC1
AACC	MAX6351SYUT	MAX	mrc	$V_{TR1} = 2.93B$; $V_{TR2} = 2.19B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 50 \text{ мкА}$	SOT23-6	RST1 • GND • MR • VCC2 • RST2 • VCC1
AACD	MAX6355LSUT	MAX	mrc	$V_{TR1} = 4.63B$; $V_{TR2} = 2.93B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 50 \text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AACE	MAX6355SYUT	MAX	mrc	$V_{TR1} = 2.93B$; $V_{TR2} = 2.19B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 50 \text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AACF	MAX6356LSUT	MAX	mrc	$V_{TR1} = 4.63B$; $V_{TR2} = 2.93B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 50 \text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AACG	MAX6356SYUT	MAX	mrc	$V_{TR1} = 2.93B$; $V_{TR2} = 2.19B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 50 \text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AACH	MAX6357LSUT	MAX	mrc	$V_{TR1} = 4.63B$; $V_{TR2} = 2.93B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 50 \text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AACI	MAX6357SYUT	MAX	mrc	$V_{TR1} = 2.93B$; $V_{TR2} = 2.19B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 50 \text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AACJ	MAX6358LSUT	MAX	mrc	$V_{TR1} = 4.63B$; $V_{TR2} = 2.93B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 50 \text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AACK	MAX6358SYUT	MAX	mrc	$V_{TR1} = 2.93B$; $V_{TR2} = 2.19B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 50 \text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AACL	MAX6359LSUT	MAX	mrc	$V_{TR1} = 4.63B$; $V_{TR2} = 2.93B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 50 \text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AACM	MAX6359SYUT	MAX	mrc	$V_{TR1} = 2.93B$; $V_{TR2} = 2.19B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 50 \text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AACN	MAX6360LSUT	MAX	mrc	$V_{TR1} = 4.63B$; $V_{TR2} = 2.93B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 50 \text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AACO	MAX6360SYUT	MAX	mrc	$V_{TR1} = 2.93B$; $V_{TR2} = 2.19B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 50 \text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AACP	MAX6342LUT	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 60 \text{ мкА}$	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACQ	MAX6342MUT	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 60 \text{ мкА}$	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACR	MAX6342TUT	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 60 \text{ мкА}$	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACS	MAX6342SUT	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 60 \text{ мкА}$	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACT	MAX6342RUT	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 60 \text{ мкА}$	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACU	MAX6342ZUT	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.33B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 60 \text{ мкА}$	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACV	MAX6343LUT	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 60 \text{ мкА}$	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACW	MAX6343MUT	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 60 \text{ мкА}$	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACX	MAX6343TUT	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 60 \text{ мкА}$	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACY	MAX6343SUT	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 60 \text{ мкА}$	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AACZ	MAX6343RUT	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 60 \text{ мкА}$	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AAD	MAX2643EXT	MAX	amp	SiGe; $V_{CC} = 2.7...5.5B$; $f_p = 800...1000 \text{ МГц}$; $I_{CC} < 7.5 \text{ мА}$	SOT363, SC88	BIAS • GND • RFIN • VCC • GND • RFOUT
AADA	MAX6343ZUT	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.33B$; $V_{DD} = 1.2...5.5B$; $I_{CC} < 60 \text{ мкА}$	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADD	MAX9011EUT	MAX	cmp	$V_{OS} < \pm 7 \text{ мВ}$; $V_{CC} = 4.5...5.5B$; $I_{CC} < 2.1 \text{ мА}$	SOT23-6	OUT • GND • IN+ • IN- • LE • VCC
AADE	MAX5363EUT	MAX	DAC	6-pasp; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7...3.6B$; $V_{REF} = 2B$	SOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AADF	MAX5383EUT	MAX	DAC	8-pasp; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7...3.6B$; $V_{REF} = 2B$	SOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AADG	MAX5364EUT	MAX	DAC	6-pasp; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 4.5...5.5B$; $V_{REF} = 4B$	SOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AADH	MAX5384EUT	MAX	DAC	8-pasp; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 4.5...5.5B$; $V_{REF} = 4B$	SOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS

fS6 SON-6
M16 USM-6SOT563
SOT666SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4+5+6
AADI	MAX3365EUT	MAX	DAC	6-паар.; SPI/OSPI/Microwire; $V_{DD}=2.7...5.5$ В; $V_{REF}=0.9 \times V_{DD}$	SOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AADJ	MAX5384EZT	MAX	DAC	8-паар.; SPI/OSPI/Microwire; $V_{DD}=4.5...5.5$ В; $V_{REF}=4$ В	TSOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AADJ	MAX5385EUT	MAX	DAC	8-паар.; SPI/OSPI/Microwire; $V_{DD}=2.7...5.5$ В; $V_{REF}=0.9 \times V_{DD}$	SOT23-6	OUT • GND • VDD • DIN • SCLK • CS
AADK	MAX4520EUT	MAX	asw	SPST; $R_{ON} < 225$ Ом; $V_{DD}=9...36$; ±4.5...±20 В	SOT23-6	V+ • V- • IN • GND • COM • NO
AADN	MAX4628EUT	MAX	asw	SPST; $R_{ON} < 12$ Ом; $V_{DD}=1.8...5.5$ В	SOT23-6	COM • NO • GND • IN • IN • V+
AADQ	MAX6344LUT	MAX	mrc	$V_{IR}=4.63$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 60$ мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADR	MAX6344MUT	MAX	mrc	$V_{IR}=4.38$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 60$ мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADS	MAX6344TUT	MAX	mrc	$V_{IR}=3.08$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 60$ мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADT	MAX6344SUT	MAX	mrc	$V_{IR}=2.93$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 60$ мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADU	MAX6344RUT	MAX	mrc	$V_{IR}=2.63$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 60$ мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADV	MAX6344ZUT	MAX	mrc	$V_{IR}=2.33$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 60$ мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADW	MAX6345LUT	MAX	mrc	$V_{IR}=4.63$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 60$ мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADX	MAX6345MUT	MAX	mrc	$V_{IR}=4.38$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 60$ мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADY	MAX6345TUT	MAX	mrc	$V_{IR}=3.08$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 60$ мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AADZ	MAX6345SUT	MAX	mrc	$V_{IR}=2.93$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 60$ мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AAEA	MAX6345RUT	MAX	mrc	$V_{IR}=2.63$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 60$ мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AAEB	MAX6345ZUT	MAX	mrc	$V_{IR}=2.33$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 60$ мкА	SOT23-6	VCC • GND • PFI • PFO • MR • RES
AAEC	MAX4323EUT	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.4...6.5$; ±1.2...±3.25 В; $f_{SD}=5$ МГц; $V_{OS} < 3.5$ мВ	SOT23-6	OUT • VEE • IN+ • IN- • SHDN • VCC
AAED	MAX6361LUT46	MAX	mrc	$V_{IR}=4.63$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEE	MAX6361LUT44	MAX	mrc	$V_{IR}=4.38$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEF	MAX6361LUT31	MAX	mrc	$V_{IR}=3.08$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEG	MAX6361LUT29	MAX	mrc	$V_{IR}=2.93$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEH	MAX6361LUT26	MAX	mrc	$V_{IR}=2.63$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEI	MAX6361LUT23	MAX	mrc	$V_{IR}=2.32$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEJ	MAX6361PUT46	MAX	mrc	$V_{IR}=4.63$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEK	MAX6361PUT44	MAX	mrc	$V_{IR}=4.38$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEL	MAX6361PUT31	MAX	mrc	$V_{IR}=3.08$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEM	MAX6361PUT29	MAX	mrc	$V_{IR}=2.93$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEN	MAX6361PUT26	MAX	mrc	$V_{IR}=2.63$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEO	MAX6361PUT23	MAX	mrc	$V_{IR}=2.32$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEP	MAX6361HUT46	MAX	mrc	$V_{IR}=4.63$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEQ	MAX6361HUT44	MAX	mrc	$V_{IR}=4.38$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAER	MAX6361HUT31	MAX	mrc	$V_{IR}=3.08$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAES	MAX6361HUT29	MAX	mrc	$V_{IR}=2.93$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAET	MAX6361HUT26	MAX	mrc	$V_{IR}=2.63$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEU	MAX6361HUT23	MAX	mrc	$V_{IR}=2.32$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • MR • VCC • OUT • BATT
AAEV	MAX6362LUT46	MAX	mrc	$V_{IR}=4.63$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAEW	MAX6362LUT44	MAX	mrc	$V_{IR}=4.38$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAEX	MAX6362LUT31	MAX	mrc	$V_{IR}=3.08$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAEY	MAX6362LUT29	MAX	mrc	$V_{IR}=2.93$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAEZ	MAX6362LUT26	MAX	mrc	$V_{IR}=2.63$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAF	MAX4599EXT	MAX	asw	SPDT; $R_{ON} < 65$ Ом; $V_{DD}=2.0...5.5$ В	SOT363, SC88	IN • V+ • GND • NC • COM • NO



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAFA	MAX6362LUT23	MAX	mrc	$V_{TR}=2.32\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFB	MAX6362PUT46	MAX	mrc	$V_{TR}=4.63\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFC	MAX6362PUT44	MAX	mrc	$V_{TR}=4.38\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFD	MAX6362PUT31	MAX	mrc	$V_{TR}=3.08\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFE	MAX6362PUT29	MAX	mrc	$V_{TR}=2.63\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFF	MAX6362PUT26	MAX	mrc	$V_{TR}=2.32\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFG	MAX6362PUT23	MAX	mrc	$V_{TR}=2.25\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFH	MAX6362HUT46	MAX	mrc	$V_{TR}=4.63\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFI	MAX6362HUT44	MAX	mrc	$V_{TR}=4.38\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFU	MAX6362HUT31	MAX	mrc	$V_{TR}=3.08\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFK	MAX6362HUT29	MAX	mrc	$V_{TR}=2.93\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFL	MAX6362HUT26	MAX	mrc	$V_{TR}=2.63\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFM	MAX6362HUT23	MAX	mrc	$V_{TR}=2.32\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • WDI • VCC • OUT • BATT
AAFN	MAX6363LUT46	MAX	mrc	$V_{TR}=4.63\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFO	MAX6363LUT44	MAX	mrc	$V_{TR}=4.38\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFP	MAX6363LUT31	MAX	mrc	$V_{TR}=3.08\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFQ	MAX6363LUT29	MAX	mrc	$V_{TR}=2.93\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFR	MAX6363LUT26	MAX	mrc	$V_{TR}=2.63\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFS	MAX6363LUT23	MAX	mrc	$V_{TR}=2.32\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFT	MAX6363PUT46	MAX	mrc	$V_{TR}=4.63\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFU	MAX6363PUT44	MAX	mrc	$V_{TR}=4.38\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFV	MAX6363PUT31	MAX	mrc	$V_{TR}=3.08\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFW	MAX6363PUT29	MAX	mrc	$V_{TR}=2.93\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFX	MAX6363PUT26	MAX	mrc	$V_{TR}=2.63\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFY	MAX6363PUT23	MAX	mrc	$V_{TR}=2.32\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAFZ	MAX6363HUT46	MAX	mrc	$V_{TR}=4.63\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAG	MAX2644EXT	MAX	amp	$\text{SiGe}; V_{CC}=2.7\dots5.5\text{ B}; f_p=2400\dots2500\text{ МГц}; I_{CC}<11\text{ мА}$	SOT363, SC88	BIAS • GND • RFIN • VCC • GND • RFOUT
AAGA	MAX6363HUT44	MAX	mrc	$V_{TR}=4.38\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT
AAGB	MAX6363HUT31	MAX	mrc	$V_{TR}=3.08\text{ B}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ B}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT

fS6 SON-6
M16 USM-6SOT563
SOT666SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAGC	MAX6363HUT29	MAX	mrc	$V_{FR}=2.93\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•BATT ON•VCC•OUT•BATT
AAGD	MAX6363HUT26	MAX	mrc	$V_{FR}=2.63\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•BATT ON•VCC•OUT•BATT
AAGE	MAX6363HUT23	MAX	mrc	$V_{FR}=2.32\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•BATT ON•VCC•OUT•BATT
AAGF	MAX6364LUT46	MAX	mrc	$V_{FR}=4.63\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGG	MAX6364LUT44	MAX	mrc	$V_{FR}=4.38\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGH	MAX6364LUT31	MAX	mrc	$V_{FR}=3.08\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGI	MAX6364LUT29	MAX	mrc	$V_{FR}=2.93\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGJ	MAX6364LUT26	MAX	mrc	$V_{FR}=2.63\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAKK	MAX6364LUT23	MAX	mrc	$V_{FR}=2.32\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGL	MAX6364PUT46	MAX	mrc	$V_{FR}=4.63\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGM	MAX6364PUT44	MAX	mrc	$V_{FR}=4.38\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGN	MAX6364PUT31	MAX	mrc	$V_{FR}=3.08\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGO	MAX6364PUT29	MAX	mrc	$V_{FR}=2.93\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGP	MAX6364PUT26	MAX	mrc	$V_{FR}=2.63\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGQ	MAX6364PUT23	MAX	mrc	$V_{FR}=2.32\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGR	MAX6364HUT46	MAX	mrc	$V_{FR}=4.63\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGS	MAX6364HUT44	MAX	mrc	$V_{FR}=4.38\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGT	MAX6364HUT31	MAX	mrc	$V_{FR}=3.08\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGU	MAX6364HUT29	MAX	mrc	$V_{FR}=2.93\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGV	MAX6364HUT26	MAX	mrc	$V_{FR}=2.63\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAGW	MAX6364HUT23	MAX	mrc	$V_{FR}=2.32\text{ В}; V_{DD}=1.2\dots5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RES•GND•RES IN•VCC•OUT•BATT
AAH	MAX9030AXT	MAX	cmp	R-R; $V_{OS}<±5\text{ мВ}; V_{DD}=2.5\dots5.5\text{ В}; I_{DD}<55\text{ мкА}$	SOT363, SC88	IN+•VSS•IN-•OUT•SHDN•VDD
AAHA	MAX6510CAUT	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.7\dots5.5\text{ В}; T_{TH}=-40\dots+125\text{ °C}; I_{CC}<165\text{ мкА}$	SOT23-6	SET•GND•OUT, OUT•HYST•OUTSET•VCC
AAHB	MAX6510HAUT	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.7\dots5.5\text{ В}; T_{TH}=-40\dots+125\text{ °C}; I_{CC}<165\text{ мкА}$	SOT23-6	SET•GND•OUT, OUT•HYST•OUTSET•VCC
AAHC	MAX4599EUT	MAX	asw	SPDT; $R_{ON}<65\text{ Ом}; V_{DD}=2.0\dots5.5\text{ В}$	SOT23-6	IN+•V+•GND•NC•COM•NO
AAHF	MAX9041AEUT	MAX	cmp + vref	R-R; $V_{OS}<±7\text{ мВ}; V_{CC}=2.5\dots5.5\text{ В}; V_{REF}=2.048\text{ В}; I_{CC}<72\text{ мкА}$	SOT23-6	OUT•VEE•IN+•IN-•REF•VCC
AAHG	MAX9051AEUT	MAX	cmp + vref	R-R; $V_{OS}<±7\text{ мВ}; V_{CC}=2.7\dots5.5\text{ В}; V_{REF}=2.500\text{ В}; I_{CC}<72\text{ мкА}$	SOT23-6	OUT•VEE•IN+•IN-•REF•VCC
AAHH	MAX9041BEUT	MAX	cmp + vref	R-R; $V_{OS}<±7\text{ мВ}; V_{CC}=2.5\dots5.5\text{ В}; V_{REF}=2.048\text{ В}; I_{CC}<72\text{ мкА}$	SOT23-6	OUT•VEE•IN+•IN-•REF•VCC
AAHI	MAX9051BEUT	MAX	cmp + vref	R-R; $V_{OS}<±7\text{ мВ}; V_{CC}=2.7\dots5.5\text{ В}; V_{REF}=2.500\text{ В}; I_{CC}<72\text{ мкА}$	SOT23-6	OUT•VEE•IN+•IN-•REF•VCC



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAHJ	MAX3188EUT	MAX	transmit	RS-232; V _{CC} = 4.5...5.6 В; f _{DR} = 256 Кбит/с; I _{CC} < 170 мкА	SOT23-6	SHDN • GND • TIN • TOUT • VEE • VCC
AAHK	MAX3189EUT	MAX	transmit	RS-232; V _{CC} = 4.5...5.6 В; f _{DR} = 1 Мбит/с; I _{CC} < 170 мкА	SOT23-6	SHDN • GND • TIN • TOUT • VEE • VCC
AAHL	MAX4645EUT	MAX	asw	SPST; R _{ON} < 3 Ом; V _{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	COM • NO • GND • IN • n. c. • V+
AAHM	MAX4646EUT	MAX	asw	SPST; R _{ON} < 3 Ом; V _{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	COM • NC • GND • IN • n. c. • V+
AAHO	MAX1736EUT42	MAX	chg	1 x Li+; V _{IN} = 4.7...22 В; V _{OUT} = 4.2 В; I _{CH} < 0.75 МА	SOT23-6	IN • GATE • GND • EN • CT • BATT
AAHP	MAX1605EUT	MAX	vcon	V _{IN} = 2.4...5.5 В; V _{OUT} = 0.8...30 В; I _{CC} < 35 мкА	SOT23-6	SHDN • VCC • SCL • TX • LIM • FB
AAHQ	MAX4644EUT	MAX	asw	SPDT; R _{ON} < 4.75 Ом; V _{DD} = 1.8...5.5 В	SOT23-6	IN • V+ • GND • NC • COM • NO
AAHR	MAX880EUT	MAX	reg	LDO; V _{IN} = 2.5...12 В; V _{OUT} = 1.25...5 В; I _{OUT} = 200 мА	SOT23-6	IN • GND • OUT • FB • SHDN • POK
AAHS	MAX8881EUT18	MAX	reg	LDO; V _{IN} = 2.5...12 В; V _{OUT} = 1.8 В; I _{OUT} = 200 мА	SOT23-6	IN • GND • OUT • FB • SHDN • POK
AAHT	MAX8881EUT25	MAX	reg	LDO; V _{IN} = 2.5...12 В; V _{OUT} = 2.5 В; I _{OUT} = 200 мА	SOT23-6	IN • GND • OUT • FB • SHDN • POK
AAHU	MAX8881EUT33	MAX	reg	LDO; V _{IN} = 2.5...12 В; V _{OUT} = 3.3 В; I _{OUT} = 200 мА	SOT23-6	IN • GND • OUT • FB • SHDN • POK
AAHV	MAX8881EUT50	MAX	reg	LDO; V _{IN} = 2.5...12 В; V _{OUT} = 5.0 В; I _{OUT} = 200 мА	SOT23-6	IN • GND • OUT • FB • SHDN • POK
AAHY	MAX6625PMUT	MAX	ds	9-pair; T _{AMB} = -55...125 °C; f _C ; V _{DD} = 3...5.5 В	SOT23-6	SDA • GND • SCL • OT • ADD • VS
AAHZ	MAX6625RMUT	MAX	ds	9-pair; T _{AMB} = -55...125 °C; f _C ; V _{DD} = 3...5.5 В	SOT23-6	SDA • GND • SCL • OT • ADD • VS
AAI	MAX2654EXT	MAX	amp	V _{CC} = 2.7...5.5 В; f _p = 1575 МГц; I _{CC} < 9.2 мА	SOT363, SC88	GND • GND • RFIN • VCC • GND • RFOUT
AAIA	MAX3190EUT	MAX	transmit	RS-232; V _{CC} = ±7.5...±12 В; f _{DR} = 460 Кбит/с; I _{CC} < 250 мкА	SOT23-6	SHDN • GND • TIN • TOUT • VEE • VCC
AAIE	MAX4561EUT	MAX	asw	SPDT; R _{ON} < 75 Ом; V _{DD} = 1.8...12 В	SOT23-6	IN • V+ • GND • NC • COM • NO
AAIJ	MAX9030AOUT	MAX	cmp	R-R; V _{OS} < ±5 мВ; V _{DD} = 2.5...5.5 В; I _{DD} < 55 мкА	SOT23-6	IN+ • VSS • IN- • OUT • SHDN • VDD
AAIK	MAX6329SHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 3.3 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIL	MAX6329SLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 3.3 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIM	MAX6329SPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 3.3 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIN	MAX6329THUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 3.3 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIO	MAX6329TLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 3.3 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIP	MAX6329TPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 3.3 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIQ	MAX6329VHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 1.8 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIR	MAX6329VLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 1.8 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIS	MAX6329VPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 1.8 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIT	MAX6329WHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 1.8 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIU	MAX6329WLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 1.8 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIV	MAX6329WPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 1.8 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIW	MAX6329YHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 2.5 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIX	MAX6329YLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 2.5 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIY	MAX6329YPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 2.5 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAIZ	MAX6329ZHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 2.5 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAJ	MAX2655EXT	MAX	amp	V _{CC} = 2.7...5.5 В; f _p = 1575 МГц; I _{CC} < 9.2 мА	SOT363, SC88	BIAS • GND • RFIN • VCC • GND • RFOUT
AAJA	MAX6329ZLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 2.5 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAJB	MAX6329ZPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 2.5 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • SHDN • RES • SET • OUT
AAJC	MAX6349SHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 3.3 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • RES • SET • OUT
AAJD	MAX6349SLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 3.3 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • RES • SET • OUT
AAJE	MAX6349SPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 3.3 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • RES • SET • OUT
AAJF	MAX6349THUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 3.3 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • RES • SET • OUT
AAJG	MAX6349TLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 3.3 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • RES • SET • OUT
AAJH	MAX6349TPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 3.3 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • RES • SET • OUT
AAJI	MAX6349VHUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 1.8 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • RES • SET • OUT
AAJJ	MAX6349VLUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 1.8 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • RES • SET • OUT
AAJK	MAX6349VPUT	MAX	reg + mrc	LDO; V _{IN} = 2.5...5.5 В; V _{OUT} = 1.8 В; I _{OUT} > 150 мА	SOT23-6	IN • GND • MR • RES • SET • OUT

f56 SON-6
M16 USM-6SOT563
SOT666SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAJL	MAX6349WHUT	MAX	reg + mrc	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5$ В; $V_{OUT}=1.8$ В; $I_{OUT}>150$ мА	SOT23-6	IN•GND•MR•RES•SET•OUT
AAJM	MAX6349WLUT	MAX	reg + mrc	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5$ В; $V_{OUT}=1.8$ В; $I_{OUT}>150$ мА	SOT23-6	IN•GND•MR•RES•SET•OUT
AAJN	MAX6349WPUT	MAX	reg + mrc	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5$ В; $V_{OUT}=1.8$ В; $I_{OUT}>150$ мА	SOT23-6	IN•GND•MR•RES•SET•OUT
AAJO	MAX6349YHUT	MAX	reg + mrc	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5$ В; $V_{OUT}=2.5$ В; $I_{OUT}>150$ мА	SOT23-6	IN•GND•MR•RES•SET•OUT
AAJP	MAX6349YLUT	MAX	reg + mrc	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5$ В; $V_{OUT}=2.5$ В; $I_{OUT}>150$ мА	SOT23-6	IN•GND•MR•RES•SET•OUT
AAJQ	MAX6349YPUT	MAX	reg + mrc	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5$ В; $V_{OUT}=2.5$ В; $I_{OUT}>150$ мА	SOT23-6	IN•GND•MR•RES•SET•OUT
AAJR	MAX6349ZHUT	MAX	reg + mrc	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5$ В; $V_{OUT}=2.5$ В; $I_{OUT}>150$ мА	SOT23-6	IN•GND•MR•RES•SET•OUT
AAJS	MAX6349ZLUT	MAX	reg + mrc	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5$ В; $V_{OUT}=2.5$ В; $I_{OUT}>150$ мА	SOT23-6	IN•GND•MR•RES•SET•OUT
AAJT	MAX6349ZPUT	MAX	reg + mrc	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5$ В; $V_{OUT}=2.5$ В; $I_{OUT}>150$ мА	SOT23-6	IN•GND•MR•RES•SET•OUT
AAJU	MAX6339AUT	MAX	mrc	$V_{IN1}=5$ В; $V_{IN2}=3.3$ В; $V_{IN3}=2.5$ В; V_{IN4} = per.; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAJV	MAX6339BUT	MAX	mrc	$V_{IN1}=5$ В; $V_{IN2}=3.3$ В; $V_{IN3}=2.5$ В; V_{IN4} = per.; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAJW	MAX6339CUT	MAX	mrc	$V_{IN1}=5$ В; $V_{IN2}=3.3$ В; $V_{IN3}=1.8$ В; V_{IN4} = per.; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAJX	MAX6339DUT	MAX	mrc	$V_{IN1}=5$ В; $V_{IN2}=3.3$ В; $V_{IN3}=1.8$ В; V_{IN4} = per.; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAJY	MAX6339EUT	MAX	mrc	$V_{IN1}=5$ В; $V_{IN2}=3$ В; $V_{IN3}=2.5$ В; V_{IN4} = per.; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAJZ	MAX6339FUT	MAX	mrc	$V_{IN1}=5$ В; $V_{IN2}=3$ В; $V_{IN3}=2.5$ В; V_{IN4} = per.; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAK	MAX2656EXT	MAX	amp	$V_{CC}=2.7...5.5$ В; $I_p=1960$ мА; $I_{CC}<9.2$ мА	SOT363, SC88	BIAS•GND•RFIN•VCC•GND•RFOUT
AAKA	MAX6339GUT	MAX	mrc	$V_{IN1}=5$ В; $V_{IN2}=3$ В; $V_{IN3}=1.8$ В; V_{IN4} = per.; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAKB	MAX6339HUT	MAX	mrc	$V_{IN1}=5$ В; $V_{IN2}=3$ В; $V_{IN3}=1.8$ В; V_{IN4} = per.; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAKC	MAX6339IUT	MAX	mrc	$V_{IN1}=5$ В; $V_{IN2}=3.3$ В; $V_{IN3}=2.5$ В; $V_{IN4}=1.8$ В; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAKD	MAX6339JUT	MAX	mrc	$V_{IN1}=5$ В; $V_{IN2}=3.3$ В; $V_{IN3}=2.5$ В; $V_{IN4}=1.8$ В; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAKE	MAX6339KUT	MAX	mrc	V_{IN1} = per.; $V_{IN2}=3.3$ В; $V_{IN3}=2.5$ В; V_{IN4} = per.; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAKF	MAX6339LUT	MAX	mrc	V_{IN1} = per.; $V_{IN2}=3.3$ В; $V_{IN3}=2.5$ В; V_{IN4} = per.; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAKG	MAX6339MUT	MAX	mrc	$V_{IN1}=5$ В; $V_{IN2}=3$ В; V_{IN3} = per.; $V_{IN4}=-5$ В; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAKH	MAX6339NUT	MAX	mrc	$V_{IN1}=5$ В; $V_{IN2}=3$ В; V_{IN3} = per.; $V_{IN4}=-5$ В; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAKI	MAX6339OUT	MAX	mrc	$V_{IN1}=5$ В; $V_{IN2}=3.3$ В; V_{IN3} = per.; $V_{IN4}=-5$ В; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAKJ	MAX6339PUT	MAX	mrc	$V_{IN1}=5$ В; $V_{IN2}=3.3$ В; V_{IN3} = per.; $V_{IN4}=-5$ В; $V_{DD}=1.0...5.5$ В; $I_{CC}<115$ мкА	SOT23-6	IN1•IN2•IN3•IN4•GND•RES
AAKK	MAX6505UTN035	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5...5.5$ В; $T_{TH}=-35$ °C; $I_{CC}<80$ мкА	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAKL	MAX6505UTN030	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5...5.5$ В; $T_{TH}=-30$ °C; $I_{CC}<80$ мкА	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAKM	MAX6505UTN025	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5...5.5$ В; $T_{TH}=-25$ °C; $I_{CC}<80$ мкА	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAKN	MAX6505UTN020	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5...5.5$ В; $T_{TH}=-20$ °C; $I_{CC}<80$ мкА	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAKO	MAX6505UTN015	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5...5.5$ В; $T_{TH}=-15$ °C; $I_{CC}<80$ мкА	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAKP	MAX6505UTN010	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5...5.5$ В; $T_{TH}=-10$ °C; $I_{CC}<80$ мкА	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAKQ	MAX6505UTN005	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5...5.5$ В; $T_{TH}=-5$ °C; $I_{CC}<80$ мкА	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAKR	MAX6505UTP000	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=0^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAKS	MAX6505UTP005	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+5^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAKT	MAX6505UTP010	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+10^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAKU	MAX6505UTP015	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+15^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAKV	MAX6505UTP020	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+20^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAKW	MAX6505UTP025	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+25^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAKX	MAX6505UTP030	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+30^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAKY	MAX6505UTP035	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+35^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAKZ	MAX6505UTP040	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+40^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAL	MAX1852EXT	MAX	vcpccon	$V_{IN}=2.5 \dots 5.5\text{В}; I_{B}=50\text{кГц}; I_{OUT}=30\text{мА}$	SOT363, SC88	OUT•GND•SHDN•IN•CI•C1+
AALA	MAX6505UTP045	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+45^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALB	MAX6505UTP050	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+50^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALC	MAX6505UTP055	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+55^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALD	MAX6505UTP060	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+60^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALE	MAX6505UTP065	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+65^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALF	MAX6505UTP070	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+70^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALG	MAX6505UTP075	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+75^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALH	MAX6505UTP080	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+80^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALI	MAX6505UTP085	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+85^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALJ	MAX6505UTP090	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+90^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALK	MAX6505UTP095	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+95^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALL	MAX6505UTP100	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+100^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALM	MAX6505UTP105	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+105^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALN	MAX6505UTP110	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+110^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALO	MAX6505UTP115	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+115^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALP	MAX6505UTP120	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+120^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALQ	MAX6505UTP125	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=+125^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALR	MAX6506UTN035	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=-35^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALS	MAX6506UTN030	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5\text{В}; T_{PH}=-30^\circ\text{C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM

fS6 SON-6 SOT563
M16 USM-6 SOT666



SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AALT	MAX6506UTN025	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=-25^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALU	MAX6506UTN020	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=-20^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALV	MAX6506UTN015	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=-15^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALW	MAX6506UTN010	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=-10^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALX	MAX6506UTN005	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=-5^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALY	MAX6506UTP000	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=0^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AALZ	MAX6506UTP005	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+5^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAM	MAX1853EXT	MAX	vcрcon	$V_{IN}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; I_F=200 \text{ кГц}; I_{OUT}=30 \text{ мА}$	SOT363, SC88	OUT•GND•SHDN•IN•C1•C1+
AAMA	MAX6506UTP010	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+10^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMB	MAX6506UTP015	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+15^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMC	MAX6506UTP020	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+20^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMD	MAX6506UTP025	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+25^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAME	MAX6506UTP030	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+30^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMF	MAX6506UTP035	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+35^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMG	MAX6506UTP040	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+40^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMH	MAX6506UTP045	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+45^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMI	MAX6506UTP050	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+50^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMJ	MAX6506UTP055	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+55^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMK	MAX6506UTP060	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+60^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAML	MAX6506UTP065	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+65^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMM	MAX6506UTP070	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+70^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMN	MAX6506UTP075	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+75^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMO	MAX6506UTP080	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+80^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMP	MAX6506UTP085	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+85^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMQ	MAX6506UTP090	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+90^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMR	MAX6506UTP095	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+95^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMS	MAX6506UTP100	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+100^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMT	MAX6506UTP105	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+105^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMU	MAX6506UTP110	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+110^\circ\text{C}; I_{CC}<80 \text{ мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM



SOT23-6 **SOT457** **SOT363**
TSOT23-6 **MW-6** **TSOT363**



SOT563 **SON-6** **fS6**
SOT666 **USM-6** **M16**

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAMV	MAX6506UTP115	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5...5.5\text{В}; T_{TH}=+115\text{°C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMW	MAX6506UTP120	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5...5.5\text{В}; T_{TH}=+120\text{°C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMX	MAX6506UTP125	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5...5.5\text{В}; T_{TH}=+125\text{°C}; I_{CC}<80\text{мкА}$	SOT23-6	WARN•GND•S1•VCC•S0•ALARM
AAMY	MAX6507UT8255	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5...5.5\text{В}; T_{THL}=-80\text{°C}; T_{THU}=+85\text{°C}; I_{CC}<60\text{мкА}$	SOT23-6	OK•GND•S0•VCC•n.c.•OVER
AAMZ	MAX6507U0A32	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5...5.5\text{В}; T_{THL}=+10\text{°C}; T_{THU}=+50\text{°C}; I_{CC}<60\text{мкА}$	SOT23-6	OK•GND•S0•VCC•n.c.•OVER
AAN	MAX4481AXT	MAX	OA	R-R; $V_{DD}=2.5...5.5\text{В}; I_{CC}<100\text{мкА}; V_{OS}<5.5\text{мВ}$	SOT363, SC88	IN+•VSS•IN-•OUT•SHDN•VDD
AANA	MAX6508UT8255	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5...5.5\text{В}; T_{THL}=-80\text{°C}; T_{THU}=+85\text{°C}; I_{CC}<60\text{мкА}$	SOT23-6	OK•GND•S0•VCC•n.c.•OVER
AANB	MAX6508U0A32	MAX	tempsw	$V_{CC}=2.5...5.5\text{В}; T_{THL}=+10\text{°C}; T_{THU}=+50\text{°C}; I_{CC}<60\text{мкА}$	SOT23-6	OK•GND•S0•VCC•n.c.•OVER
AANC	MAX1736EUT41	MAX	chg	$1\times\text{Li+}; V_{IN}=4.7...22\text{В}; V_{OUT}=4.1\text{В}; I_{CH}<0.75\text{мА}$	SOT23-6	IN•GATE•GND•EN•CT•BATT
AAND	MAX4675EUT	MAX	asw	SPST; $R_{ON}<40\text{м}\Omega; V_{DD}=2.7...5.5/2.7...4.5\text{В}$	SOT23-6	V+•COM•V-•GND•NO•IN
AANE	MAX4676EUT	MAX	asw	SPST; $R_{ON}<40\text{м}\Omega; V_{DD}=2.7...5.5/2.7...4.5\text{В}$	SOT23-6	V+•COM•V-•GND•NC•IN
AANF	MAX1818EUT25	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5\text{В}; V_{OUT}=2.5/1.25...5\text{В}; I_{OUT}=500\text{мА}$	SOT23-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AANG	MAX1818EUT33	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5\text{В}; V_{OUT}=3.3/1.25...5\text{В}; I_{OUT}=500\text{мА}$	SOT23-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AANH	MAX1818EUT50	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5\text{В}; V_{OUT}=5.0/1.25...5\text{В}; I_{OUT}=500\text{мА}$	SOT23-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AANI	MAX6351LRUT	MAX	mrc	$V_{TR1}=4.63\text{В}; V_{TR2}=2.63\text{В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{В}; I_{CC}<50\text{мкА}$	SOT23-6	RST1•GND•MR•VCC2•RST2•VCC1
AANL	MAX1755BAUT	MAX	ltcmp	SMBUS; $V_{CC}=2.375...5.5\text{В}; T_{THAC}=\pm 3\text{°C}; I_{CC}<200\text{мкА}$	SOT23-6	ADD•SMBDATA•SMBCLK•OVERT•VCC•GND
AANM	MAX1755AAUT	MAX	ltcmp	SMBUS; $V_{CC}=2.375...5.5\text{В}; T_{THAC}=\pm 3\text{°C}; I_{CC}<200\text{мкА}$	SOT23-6	ADD•SMBDATA•SMBCLK•OVERT•VCC•GND
AANN	MAX1756BAUT	MAX	ltcmp	SMBUS; $V_{CC}=2.375...5.5\text{В}; T_{THAC}=\pm 3\text{°C}; I_{CC}<200\text{мкА}$	SOT23-6	ADD•SMBDATA•SMBCLK•ALERT•VCC•GND
AANO	MAX1756AAUT	MAX	ltcmp	SMBUS; $V_{CC}=2.375...5.5\text{В}; T_{THAC}=\pm 3\text{°C}; I_{CC}<200\text{мкА}$	SOT23-6	ADD•SMBDATA•SMBCLK•ALERT•VCC•GND
AANP	MAX6626PMUT	MAX	dts	12-паар.; $T_{AMB}=-55...125\text{°C}; I^2\text{C}; V_{DD}=3...5.5\text{В}$	SOT23-6	SDA•GND•SCL•OT•ADD•VS
AANQ	MAX6626RMUT	MAX	dts	12-паар.; $T_{AMB}=-55...125\text{°C}; I^2\text{C}; V_{DD}=3...5.5\text{В}$	SOT23-6	SDA•GND•SCL•OT•ADD•VS
AANT	MAX6355MRUT	MAX	mrc	$V_{TR1}=4.38\text{В}; V_{TR2}=2.63\text{В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{В}; I_{CC}<50\text{мкА}$	SOT23-6	RST•GND•MR•VCC2•RSTIN•VCC1
AANU	MAX1818EUT18	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5\text{В}; V_{OUT}=1.8/1.25...5\text{В}; I_{OUT}=500\text{мА}$	SOT23-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AANV	MAX1818EUT20	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5\text{В}; V_{OUT}=2.0/1.25...5\text{В}; I_{OUT}=500\text{мА}$	SOT23-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AANW	MAX1836EUT50	MAX	vcon	$V_{IN}=4.5...24\text{В}; V_{OUT}=5\text{В}; I_{OUT}<125\text{мА}$	SOT23-6	FB•GND•IN•LX•SHDN•OUT
AANX	MAX1837EUT50	MAX	vcon	$V_{IN}=4.5...24\text{В}; V_{OUT}=5\text{В}; I_{OUT}<250\text{мА}$	SOT23-6	FB•GND•IN•LX•SHDN•OUT
AANY	MAX1836EUT33	MAX	vcon	$V_{IN}=4.5...24\text{В}; V_{OUT}=3.3\text{В}; I_{OUT}<125\text{мА}$	SOT23-6	FB•GND•IN•LX•SHDN•OUT
AANZ	MAX1837EUT33	MAX	vcon	$V_{IN}=4.5...24\text{В}; V_{OUT}=3.3\text{В}; I_{OUT}<250\text{мА}$	SOT23-6	FB•GND•IN•LX•SHDN•OUT
AAO	MAX3371EXT	MAX	levtrans	RS-232; $V_{CC}=2.5...5.5\text{В}; I_{DR}=2\text{Мбит/с}; I_{CC}<100\text{мкА}$	SOT363, SC88	SHDN•I/OVL•I/OVCC•SHDN•VCC
AAOA	MAX6511UT045	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0...5.5\text{В}; T_{TH}=+45\text{°C}; I_{CC}<600\text{мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOB	MAX6511UT055	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0...5.5\text{В}; T_{TH}=+55\text{°C}; I_{CC}<600\text{мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOC	MAX6511UT065	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0...5.5\text{В}; T_{TH}=+65\text{°C}; I_{CC}<600\text{мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOD	MAX6511UT075	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0...5.5\text{В}; T_{TH}=+75\text{°C}; I_{CC}<600\text{мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP

f56 SON-6
M16 USM-6SOT563
SOT666SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAOE	MAX6511UT085	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+85^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOF	MAX6511UT095	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+95^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOG	MAX6511UT105	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+105^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOH	MAX6511UT115	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+115^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOI	MAX6511UT125	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+125^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOJ	MAX6512UT045	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+45^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOK	MAX6512UT055	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+55^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOL	MAX6512UT065	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+65^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOM	MAX6512UT075	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+75^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAON	MAX6512UT085	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+85^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOO	MAX6512UT095	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+95^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOP	MAX6512UT105	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+105^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOQ	MAX6512UT115	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+115^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOR	MAX6512UT125	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+125^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAOS	MAX4481AUT	MAX	OA	R•R; $V_{DD}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; I_{CC}<100 \text{ мкА}; V_{OS}<5 \text{ мВ}$	SOT23-6	IN•VSS•IN•OUT•SHDN•VDD
AAOT	MAX1832EUT	MAX	vcon	$V_{IN}=1.5 \dots 5.5 \text{ В}; V_{OUT}=2 \dots 5.5 \text{ В}; I_{OUT}<150 \text{ мА}$	SOT23-6	SHDN•BATT•GND•LX•OUT•FB
AAOU	MAX1833EUT	MAX	vcon	$V_{IN}=1.5 \dots 5.5 \text{ В}; V_{OUT}=3.3 \text{ В}; I_{OUT}<150 \text{ мА}$	SOT23-6	SHDN•BATT•GND•LX•OUT•RST
AAOV	MAX1834EUT	MAX	vcon	$V_{IN}=1.5 \dots 5.5 \text{ В}; V_{OUT}=2 \dots 5.5 \text{ В}; I_{OUT}<150 \text{ мА}$	SOT23-6	SHDN•BATT•GND•LX•OUT•FB
AAOW	MAX1835EUT	MAX	vcon	$V_{IN}=1.5 \dots 5.5 \text{ В}; V_{OUT}=3.3 \text{ В}; I_{OUT}<150 \text{ мА}$	SOT23-6	SHDN•BATT•GND•LX•OUT•RST
AAOX	MAX1522EUT	MAX	bcontr	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; I_{CC}<50 \text{ мкА}; T_{AMB}=-40 \dots 85^\circ \text{C}$	SOT23-6	GND•FB•SET•SHDN•EXT•VCC
AAOY	MAX1523EUT	MAX	bcontr	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; I_{CC}<50 \text{ мкА}; T_{AMB}=-40 \dots 85^\circ \text{C}$	SOT23-6	GND•FB•SET•SHDN•EXT•VCC
AAOZ	MAX1524EUT	MAX	bcontr	$V_{CC}=2.5 \dots 5.5 \text{ В}; I_{CC}<50 \text{ мкА}; T_{AMB}=-40 \dots 85^\circ \text{C}$	SOT23-6	GND•FB•SET•SHDN•EXT•VCC
AAP	MAX5461EXT	MAX	Dpot	32 позиции; $100 \text{ кОм}; V_{DD}=2.7 \dots 5.5 \text{ В}$	SOT363, SC88	VDD•GND•U/D•CS•L•H
AAPD	MAX6513UT045	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+45^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAPE	MAX6513UT055	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+55^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAPF	MAX6513UT065	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+65^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAPG	MAX6513UT075	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+75^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAPH	MAX6513UT085	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+85^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAPI	MAX6513UT095	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+95^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAPJ	MAX6513UT105	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+105^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP
AAPK	MAX6513UT115	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0 \dots 5.5 \text{ В}; T_{TH}=+115^\circ \text{C}; I_{CC}<600 \text{ мкА}$	SOT23-6	VDD•GND•HYST•TOVER•DXN•DXP



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AAPL	MAX6613UT12S	MAX	tempsw	$V_{CC}=3.0...5.5\text{ В}; T_{PH}=+125\text{ }^{\circ}\text{C}; I_{CC}<600\text{ мкА}$	SOT23-6	VDD • GND • HYST • TOVER • DXN • DXP
AAPM	MAX6629MUT	MAX	dts	12-разр.+знак; $T_{AMB}=-55...125\text{ }^{\circ}\text{C}$; SPI; $V_{DD}=3...5.5\text{ В}; I_{CC}=200\text{ мкА}$	SOT23-6	п. с. • GND • VCC • SCK • CS • SO
AAPN	MAX6630MUT	MAX	dts	12-разр.+знак; $T_{AMB}=-55...125\text{ }^{\circ}\text{C}$; SPI; $V_{DD}=3...5.5\text{ В}; I_{CC}=200\text{ мкА}$	SOT23-6	GND • п. с. • VCC • SCK • CS • SO
AAPO	MAX6631MUT	MAX	dts	12-разр.+знак; $T_{AMB}=-55...125\text{ }^{\circ}\text{C}$; SPI; $V_{DD}=3...5.5\text{ В}; I_{CC}=30\text{ мкА}$	SOT23-6	п. с. • GND • VCC • SCK • CS • SO
AAPP	MAX6632MUT	MAX	dts	12-разр.+знак; $T_{AMB}=-55...125\text{ }^{\circ}\text{C}$; SPI; $V_{DD}=3...5.5\text{ В}; I_{CC}=30\text{ мкА}$	SOT23-6	GND • п. с. • VCC • SCK • CS • SO
AAPQ	MAX6826SUT	MAX	mrc + wdt	$V_{TR}=2.93\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<30\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • RES IN • VCC
AAPR	MAX6827RUT	MAX	mrc + wdt	$V_{TR}=2.63\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<30\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • RES IN • VCC
AAPS	MAX6828YUT	MAX	mrc + wdt	$V_{TR}=2.19\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<30\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • RES IN • VCC
AAPT	MAX6829SVUT	MAX	mrc + wdt	$V_{TR1}=2.93\text{ В}; V_{TR2}=1.575\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<30\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • VCC2 • VCC
AAPU	MAX6830ZGUT	MAX	mrc + wdt	$V_{TR1}=2.32\text{ В}; V_{TR2}=1.11\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<30\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • VCC2 • VCC
AAPV	MAX6831VDUT	MAX	mrc + wdt	$V_{TR1}=1.58\text{ В}; V_{TR2}=0.788\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<30\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • VCC2 • VCC
AAQ	MAX5462EXT	MAX	Dpot	32 позиции; $100\text{ кОм}; V_{DD}=2.7...5.5\text{ В}$	SOT363, SC88	VDD • GND • U/D • CS • W • H
AAQA	MAX6351UVUT	MAX	mrc	$V_{TR1}=2.78\text{ В}; V_{TR2}=1.58\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST1 • GND • MR • VCC2 • RST2 • VCC1
AAQB	MAX6358RWUT	MAX	mrc	$V_{TR1}=2.63\text{ В}; V_{TR2}=1.67\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AAQC	MAX6359TWUT	MAX	mrc	$V_{TR1}=2.93\text{ В}; V_{TR2}=2.19\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AAQD	MAX6360RVUT	MAX	mrc	$V_{TR1}=2.63\text{ В}; V_{TR2}=1.58\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AAQE	MAX6355TVUT	MAX	mrc	$V_{TR1}=3.08\text{ В}; V_{TR2}=1.58\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AAQF	MAX6356SWUT	MAX	mrc	$V_{TR1}=2.93\text{ В}; V_{TR2}=1.67\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AAQG	MAX6357UVUT	MAX	mrc	$V_{TR1}=2.78\text{ В}; V_{TR2}=1.58\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AAQH	MAX6355TYUT	MAX	mrc	$V_{TR1}=3.08\text{ В}; V_{TR2}=2.19\text{ В}; V_{DD}=1.2...5.5\text{ В}; I_{CC}<50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AAQJ	MAX5900AAEUT	MAX	hscontr	$V_{EE}=-100...-9\text{ В}; I_{CC}<1.3\text{ мА}; V_{CB}=200\text{ мВ}$	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQK	MAX5900ABEUT	MAX	hscontr	$V_{EE}=-100...-9\text{ В}; I_{CC}<1.3\text{ мА}; V_{CB}=300\text{ мВ}$	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQL	MAX5900ACEUT	MAX	hscontr	$V_{EE}=-100...-9\text{ В}; I_{CC}<1.3\text{ мА}; V_{CB}=400\text{ мВ}$	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQM	MAX5900LAEUT	MAX	hscontr	$V_{EE}=-100...-9\text{ В}; I_{CC}<1.3\text{ мА}; V_{CB}=200\text{ мВ}$	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQN	MAX5900LBEUT	MAX	hscontr	$V_{EE}=-100...-9\text{ В}; I_{CC}<1.3\text{ мА}; V_{CB}=300\text{ мВ}$	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQO	MAX5900LCEUT	MAX	hscontr	$V_{EE}=-100...-9\text{ В}; I_{CC}<1.3\text{ мА}; V_{CB}=400\text{ мВ}$	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQP	MAX5901AAEUT	MAX	hscontr	$V_{EE}=-100...-9\text{ В}; I_{CC}<1.3\text{ мА}; V_{CB}=200\text{ мВ}$	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQQ	MAX5901ABEUT	MAX	hscontr	$V_{EE}=-100...-9\text{ В}; I_{CC}<1.3\text{ мА}; V_{CB}=300\text{ мВ}$	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQR	MAX5901ACEUT	MAX	hscontr	$V_{EE}=-100...-9\text{ В}; I_{CC}<1.3\text{ мА}; V_{CB}=400\text{ мВ}$	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF

fS6 SON-6
M16 USM-6SOT563
SOT666SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4+5+6
AAQS	MAX5901LAEUT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100 \dots -9\text{ В}; I_{CC} < 1.3\text{ мА}; V_{CB} = 200\text{ мВ}$	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQT	MAX5901LBEUT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100 \dots -9\text{ В}; I_{CC} < 1.3\text{ мА}; V_{CB} = 300\text{ мВ}$	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQU	MAX5901LCEUT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100 \dots -9\text{ В}; I_{CC} < 1.3\text{ мА}; V_{CB} = 400\text{ мВ}$	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQV	MAX5900NNEUT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100 \dots -9\text{ В}; I_{CC} < 1.3\text{ мА}$	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQW	MAX5901NNEUT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100 \dots -9\text{ В}; I_{CC} < 1.3\text{ мА}$	SOT23-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AAQX	MAX6826TUT	MAX	mrc + wdt	$V_{FR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 30\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • RES IN • VCC
AAQY	MAX6827LUT	MAX	mrc + wdt	$V_{FR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 30\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • RES IN • VCC
AAQZ	MAX6829SHUT	MAX	mrc + wdt	$V_{FR1} = 2.93\text{ В}; V_{FR2} = 1.313\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 30\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • VCC2 • VCC
AAR	MAX5464EXT	MAX	Dpot	32 позиции; 50 кОм; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5\text{ В}$	SOT363, SC88	VDD • GND • U/D • CS • L • H
AARA	MAX6830YGUT	MAX	mrc + wdt	$V_{FR1} = 2.19\text{ В}; V_{FR2} = 1.11\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 30\text{ мкА}$	SOT23-6	RES • GND • MR • WDI • VCC2 • VCC
AARB	MAX6323CUT46	MAX	mrc	$V_{FR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 57\text{ мкА}$	SOT23-6	MR • GND • WDI • VCC • WDP0 • RES
AARC	MAX6324HUT31	MAX	mrc	$V_{FR} = 3.00\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 57\text{ мкА}$	SOT23-6	MR • GND • WDI • VCC • WDP0 • RES
AARD	MAX6323FUT23	MAX	mrc	$V_{FR} = 2.25\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 57\text{ мкА}$	SOT23-6	MR • GND • WDI • VCC • WDP0 • RES
AARE	MAX6324AUT46	MAX	mrc	$V_{FR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 57\text{ мкА}$	SOT23-6	MR • GND • WDI • VCC • WDP0 • RES
AARF	MAX6819UT	MAX	vseq	$V_{FR} = 0.62\text{ В}; V_{CC} = 0.9 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 120\text{ мкА}$	SOT23-6	VCC1 • GND • SETV • EN • GATE • VCC2
AARG	MAX6820UT	MAX	vseq	$V_{FR} = 0.62\text{ В}; V_{CC} = 0.9 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 120\text{ мкА}$	SOT23-6	VCC1 • GND • SETV • SETD • GATE • VCC2
AARH	MAX5467EUT	MAX	Dpot	32 позиции; 10 кОм; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5\text{ В}$	SOT23-6	VDD • GND • U/D • CS • L • H
AARI	MAX5468EUT	MAX	Dpot	32 позиции; 10 кОм; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5\text{ В}$	SOT23-6	VDD • GND • U/D • CS • W • H
AARJ	MAX6323AUT29	MAX	mrc	$V_{FR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 57\text{ мкА}$	SOT23-6	MR • GND • WDI • VCC • WDP0 • RES
AARK	MAX6351RVUT	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.63\text{ В}; V_{FR2} = 1.58\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST1 • GND • MR • VCC2 • RST2 • VCC1
AARL	MAX6356RWUT	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.63\text{ В}; V_{FR2} = 1.67\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AARM	MAX6357UWUT	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.78\text{ В}; V_{FR2} = 1.67\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AARN	MAX6358TWUT	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.93\text{ В}; V_{FR2} = 2.19\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AARO	MAX6358SVUT	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.93\text{ В}; V_{FR2} = 1.58\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AARP	MAX6359RVUT	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.63\text{ В}; V_{FR2} = 1.58\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AARQ	MAX6360SWUT	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.93\text{ В}; V_{FR2} = 1.67\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AARR	MAX6355RWUT	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.63\text{ В}; V_{FR2} = 1.67\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AARS	MAX6356UVUT	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.78\text{ В}; V_{FR2} = 1.58\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • RSTIN • VCC1
AART	MAX6359UVUT	MAX	mrc	$V_{FR1} = 2.78\text{ В}; V_{FR2} = 1.58\text{ В}; V_{DD} = 1.2 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-6	RST • GND • MR • VCC2 • WDI • VCC1
AARU	MAX9109EUT	MAX	cmp	$V_{OS} < 4\text{ мВ}; V_{CC} = 4.5 \dots 5.5\text{ В}; I_{CC} < 0.7\text{ мА}$	SOT23-6	OUT • GND • IN+ • IN- • LE • VCC
AARV	MAX4647EUT	MAX	asw	SPST; $R_{ON} < 30\text{ Ом}; V_{DD} = 9 \dots 36 / 24 \dots 5 \dots \pm 20\text{ В}$	SOT23-6	NC • V+ • IN • GND • V+ • COM



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
AARW	MAX4648EUT	MAX	asw	SPST; $R_{ON} < 30 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 9...36/24.5...20 \text{ В}$	SOT23-6	NO•V•IN•GND•Vf•COM
AARX	MAX4289EUT	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 1.0...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 40 \text{ мкА}$; $V_{OS} < 6 \text{ мВ}$	SOT23-6	OUT•GND•IN+•IN-•n.c.•VCC
AAS	MAX5466EXT	MAX	Dpot	32 позиции; 50 Ом; $V_{DD} = 2.7...5.5 \text{ В}$	SOT363, SC88	VDD•GND•U/D•CS•W•H
AASA	MAX5902AAEUT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72 \text{ В}$; $I_{CC} < 2 \text{ мА}$; $V_{CB} = 300 \text{ мВ}$	SOT23-6	VS•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF
AASB	MAX5902ABEUT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72 \text{ В}$; $I_{CC} < 2 \text{ мА}$; $V_{CB} = 400 \text{ мВ}$	SOT23-6	VS•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF
AASC	MAX5902ACEUT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72 \text{ В}$; $I_{CC} < 2 \text{ мА}$; $V_{CB} = 500 \text{ мВ}$	SOT23-6	VS•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF
AASD	MAX5902LAEUT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72 \text{ В}$; $I_{CC} < 2 \text{ мА}$; $V_{CB} = 300 \text{ мВ}$	SOT23-6	VS•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF
AASE	MAX5902LBEUT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72 \text{ В}$; $I_{CC} < 2 \text{ мА}$; $V_{CB} = 400 \text{ мВ}$	SOT23-6	VS•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF
AASF	MAX5902LCEUT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72 \text{ В}$; $I_{CC} < 2 \text{ мА}$; $V_{CB} = 500 \text{ мВ}$	SOT23-6	VS•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF
AASG	MAX5903AAEUT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72 \text{ В}$; $I_{CC} < 2 \text{ мА}$; $V_{CB} = 300 \text{ мВ}$	SOT23-6	VS•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF
AASH	MAX5903ABEUT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72 \text{ В}$; $I_{CC} < 2 \text{ мА}$; $V_{CB} = 400 \text{ мВ}$	SOT23-6	VS•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF
AASI	MAX5903ACEUT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72 \text{ В}$; $I_{CC} < 2 \text{ мА}$; $V_{CB} = 500 \text{ мВ}$	SOT23-6	VS•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF
AASJ	MAX5903LAEUT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72 \text{ В}$; $I_{CC} < 2 \text{ мА}$; $V_{CB} = 300 \text{ мВ}$	SOT23-6	VS•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF
AASK	MAX5903LBEUT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72 \text{ В}$; $I_{CC} < 2 \text{ мА}$; $V_{CB} = 400 \text{ мВ}$	SOT23-6	VS•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF
AASL	MAX5903LCEUT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72 \text{ В}$; $I_{CC} < 2 \text{ мА}$; $V_{CB} = 500 \text{ мВ}$	SOT23-6	VS•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF
AASM	MAX5902NNEUT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72 \text{ В}$; $I_{CC} < 2 \text{ мА}$	SOT23-6	VS•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF
AASN	MAX5903NNEUT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72 \text{ В}$; $I_{CC} < 2 \text{ мА}$	SOT23-6	VS•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF
AASO	MAX1818EUT15	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5...5.5 \text{ В}$; $V_{OUT} = 1.5/1.25...5 \text{ В}$; $I_{OUT} = 500 \text{ мА}$	SOT23-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AASP	MAX6355MSUT	MAX	mrc	$V_{TR1} = 4.38 \text{ В}$; $V_{TR2} = 2.93 \text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 50 \text{ мкА}$	SOT23-6	RST•GND•MR•VCC2•RSTIN•VCC1
AASQ	MAX5021EUT	MAX	PWM	$V_{IN} = 11...28 \text{ В}$; DT < 50%; $I_{CC} < 2.43 \text{ мА}$	SOT23-6	CS•GND•NDRV•VCC•VIN•OPTO
AASR	MAX5022EUT	MAX	PWM	$V_{IN} = 11...28 \text{ В}$; DT < 70%; $I_{CC} < 2.43 \text{ мА}$	SOT23-6	CS•GND•NDRV•VCC•VIN•OPTO
AAT	MAX1474AXT	MAX	flecap	C = 6.4...13.3 нФ; цифровой интерфейс; $V_{DD} = 4.5...5.5 \text{ В}$	SOT363, SC88	CP•VDD•EN•DAT•VSS•CM
AAU	MAX9109EXT	MAX	cmp	$V_{OS} < 4 \text{ мВ}$; $V_{CC} = 4.5...5.5 \text{ В}$; $I_{CC} < 0.7 \text{ мА}$	SOT363, SC88	OUT•GND•IN+•IN-•LE•VCC
AAV	MAX4380EXT	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 4.5...11/22.25...5.5 \text{ В}$; $I_{BD} = 210 \text{ мГЦ}$; $V_{OS} < 20 \text{ мВ}$	SOT363, SC88	OUT•VEE•IN+•IN-•DISABLE•VCC
AAHX	MAX6033CAUT25	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6 \text{ В}$; AC < ±0.1%; $V_{OUT} = 2.500 \text{ В}$	SOT23-6	i.c. • GND • i.c. • IN • OUTF • OUTS
AAXI	MAX6033CAUT30	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6 \text{ В}$; AC < ±0.1%; $V_{OUT} = 3.000 \text{ В}$	SOT23-6	i.c. • GND • i.c. • IN • OUTF • OUTS
AAJX	MAX6033CAUT41	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6 \text{ В}$; AC < ±0.1%; $V_{OUT} = 4.096 \text{ В}$	SOT23-6	i.c. • GND • i.c. • IN • OUTF • OUTS
AAKX	MAX6033CAUT50	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6 \text{ В}$; AC < ±0.1%; $V_{OUT} = 5.000 \text{ В}$	SOT23-6	i.c. • GND • i.c. • IN • OUTF • OUTS
AAXL	MAX6033BAUT25	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6 \text{ В}$; AC < ±0.2%; $V_{OUT} = 2.500 \text{ В}$	SOT23-6	i.c. • GND • i.c. • IN • OUTF • OUTS
AAXM	MAX6033BAUT30	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6 \text{ В}$; AC < ±0.2%; $V_{OUT} = 3.000 \text{ В}$	SOT23-6	i.c. • GND • i.c. • IN • OUTF • OUTS
AAHX	MAX6033BAUT41	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6 \text{ В}$; AC < ±0.2%; $V_{OUT} = 4.096 \text{ В}$	SOT23-6	i.c. • GND • i.c. • IN • OUTF • OUTS
AAXO	MAX6033BAUT50	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6 \text{ В}$; AC < ±0.2%; $V_{OUT} = 5.000 \text{ В}$	SOT23-6	i.c. • GND • i.c. • IN • OUTF • OUTS
ABDF	MAX6033AAUT25	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6 \text{ В}$; AC < ±0.04%; $V_{OUT} = 2.500 \text{ В}$	SOT23-6	i.c. • GND • i.c. • IN • OUTF • OUTS
ABDG	MAX6033AAUT30	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6 \text{ В}$; AC < ±0.04%; $V_{OUT} = 3.000 \text{ В}$	SOT23-6	i.c. • GND • i.c. • IN • OUTF • OUTS

f56 SON-6
M16 USM-6

SOT563
SOT666



SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
ABDH	MAX6033AAUT41	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6\text{ В}$; $AC < \pm 0.04\%$; $V_{OUT} = 4.096\text{ В}$	SOT23-6	1. c. • GND • 1. c. • IN • OUTF • OUTS
ABDI	MAX6033AAUT50	MAX	vref	$V_{IN} = 2.7...12.6\text{ В}$; $AC < \pm 0.04\%$; $V_{OUT} = 5.000\text{ В}$	SOT23-6	1. c. • GND • 1. c. • IN • OUTF • OUTS
ABEC	MAX5048AAUT	MAX	drv	KMOP-вход; $V_{CC} = 4...12.6\text{ В}$; $I_{OUT} < 7.6/1.3\text{ А}$	SOT23-6	V+ • P_OUT • N_OUT • GND • IN • IN+
ABED	MAX5048BAUT	MAX	drv	ТТЛ-вход; $V_{CC} = 4...12.6\text{ В}$; $I_{OUT} < 7.6/1.3\text{ А}$	SOT23-6	V+ • P_OUT • N_OUT • GND • IN • IN+
ABQS	MAX3190EUT	MAX	transmit	RS-232; $V_{CC} = \pm 7.5... \pm 12\text{ В}$; $f_{DR} = 460\text{ Кбит/с}$; $I_{CC} < 250\text{ мкА}$	SOT23-6	SHDN • GND • TIN • TOUT • VEE • VCC
AD0	ADS1100A1DBV	TI	ADC	16-разр.; I ² C; адрес 1001000; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN-
AD1	ADS1100A1DBV	TI	ADC	16-разр.; I ² C; адрес 1001001; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN-
AD2	ADS1100A2DBV	TI	ADC	16-разр.; I ² C; адрес 1001010; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN-
AD3	ADS1100A3DBV	TI	ADC	16-разр.; I ² C; адрес 1001011; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN-
AD4	ADS1100A4DBV	TI	ADC	16-разр.; I ² C; адрес 1001100; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN-
AD5	ADS1100A5DBV	TI	ADC	16-разр.; I ² C; адрес 1001101; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN-
AD6	ADS1100A6DBV	TI	ADC	16-разр.; I ² C; адрес 1001110; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN-
AD7	ADS1100A7DBV	TI	ADC	16-разр.; I ² C; адрес 1001111; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-6	VIN+ • GND • SCL • SDA • VDD • VIN-
AK	HSMS280K	HP	shd x2	$V_{BE} > 70\text{ В}$; $V_{F(I_F = 15\text{ мА})} < 1.0\text{ В}$; $I_{H(V_{BE} = 50\text{ В})} < 200\text{ нА}$; $C_D < 2.0\text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1 • n. c. • A2 • K2 • n. c. • K1
AL	HSMS280L	HP	shd x3	$V_{BE} > 70\text{ В}$; $V_{F(I_F = 15\text{ мА})} < 1.0\text{ В}$; $I_{H(V_{BE} = 50\text{ В})} < 200\text{ нА}$; $C_D < 2.0\text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1 • A2 • A3 • K3 • K2 • K1
AM	HSMS280M	HP	shd x4	$V_{BE} > 70\text{ В}$; $V_{F(I_F = 15\text{ мА})} < 1.0\text{ В}$; $I_{H(V_{BE} = 50\text{ В})} < 200\text{ нА}$; $C_D < 2.0\text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1 • K1, K2, K3, K4 • A2 • A3 • K1, K2, K3, K4 • A4
AN	HSMS280N	HP	shd x4	$V_{BE} > 70\text{ В}$; $V_{F(I_F = 15\text{ мА})} < 1.0\text{ В}$; $I_{H(V_{BE} = 50\text{ В})} < 200\text{ нА}$; $C_D < 2.0\text{ нФ}$	SOT363, SC88	K1 • A1, A2, A3, A4 • K2 • K3 • A1, A2, A3, A4 • K4
AP	HSMS280P	HP	shd x4	$V_{BE} > 70\text{ В}$; $V_{F(I_F = 15\text{ мА})} < 1.0\text{ В}$; $I_{H(V_{BE} = 50\text{ В})} < 200\text{ нА}$; $C_D < 2.0\text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1 • K1, A2 • K2 • K3 • K4, A3 • A4
B1	IMB1A	ROHM	Dpnp x2	$V_{CC} = 50\text{ В}$; $I_{OUT} = 30\text{ мА}$; $P_D = 300\text{ мВт}$; $h_{21} > 56$; $2.2\text{ кОм}/22\text{ кОм}$	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
B1	UMB1N	ROHM	Dpnp x2	$V_{CC} = 50\text{ В}$; $I_{OUT} = 30\text{ мА}$; $P_D = 150\text{ мВт}$; $h_{21} > 56$; $2.2\text{ кОм}/22\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B10	EMB10	ROHM	Dpnp x2	$V_{CC} = 50\text{ В}$; $I_{OUT} = 100\text{ мА}$; $P_D = 150\text{ мВт}$; $h_{21} > 80$; $2.2\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B10	IMB10A	ROHM	Dpnp x2	$V_{CC} = 50\text{ В}$; $I_{OUT} = 100\text{ мА}$; $P_D = 300\text{ мВт}$; $h_{21} > 80$; $2.2\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
B10	UMB10N	ROHM	Dpnp x2	$V_{CC} = 50\text{ В}$; $I_{OUT} = 100\text{ мА}$; $P_D = 150\text{ мВт}$; $h_{21} > 80$; $2.2\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B11	EMB11	ROHM	Dpnp x2	$V_{CC} = 50\text{ В}$; $I_{OUT} = 100\text{ мА}$; $P_D = 150\text{ мВт}$; $h_{21} > 30$; $10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B11	IMB11A	ROHM	Dpnp x2	$V_{CC} = 50\text{ В}$; $I_{OUT} = 100\text{ мА}$; $P_D = 300\text{ мВт}$; $h_{21} > 30$; $10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
B11	UMB11N	ROHM	Dpnp x2	$V_{CC} = 50\text{ В}$; $I_{OUT} = 100\text{ мА}$; $P_D = 150\text{ мВт}$; $h_{21} > 30$; $10\text{ кОм}/10\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B16	IMB16	ROHM	Dpnp x2	$V_{CC} = 50\text{ В}$; $I_{OUT} = 500\text{ мА}$; $P_D = 300\text{ мВт}$; $h_{21} > 30$; $R2/R1 = 2.1$	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
B17	IMB17A	ROHM	Dpnp x2	$V_{CC} = 50\text{ В}$; $I_{OUT} = 100\text{ мА}$; $P_D = 300\text{ мВт}$; $h_{21} > 33$; $R2/R1 = 10$	SOT23-6	C1 • B1 • C2 • E2 • B2 • E1
B2	EMB2	ROHM	Dpnp x2	$V_{CC} = 50\text{ В}$; $I_{OUT} = 30\text{ мА}$; $P_D = 150\text{ мВт}$; $h_{21} > 68$; $47\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
B2	IMB2A	ROHM	Dpnp x2	$V_{CC} = 50\text{ В}$; $I_{OUT} = 30\text{ мА}$; $P_D = 300\text{ мВт}$; $h_{21} > 68$; $47\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
B2	UMB2N	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=30\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>68;$ $47\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2 •E2•B2 •C1
B3	EMB3	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_1, 4.7\text{ кОм}$	SOT563, EMT6	E1•B1•C2 •E2•B2 •C1
B3	IMB3A	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_1, 4.7\text{ кОм}$	SOT23-6	C1•B2 •E2•C2 •B1•E1
B3	UMB3N	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_1, 4.7\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2 •E2•B2 •C1
B4	EMB4	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_1, 10\text{ кОм}$	SOT563, EMT6	E1•B1•C2 •E2•B2 •C1
B4	IMB4A	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_1, 10\text{ кОм}$	SOT23-6	C1•B2 •E2•C2 •B1•E1
B4	UMB4N	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_1, 10\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2 •E2•B2 •C1
B5	IMB5A	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>56;$ $R2/R1=1$	SOT23-6	C1•B1•C2•B2 •E2•C1
B5	UMBSN	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>56;$ $R2/R1=22\text{ кОм}/22\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•E2•B2 •C2 •B1•C1
B6	EMB6	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=50\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>68;$ $R2/R1=1$	SOT563, EMT6	C1•B1•C2•B2 •E2•E1
B6	IMB6A	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=50\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>68;$ $R2/R1=1$	SOT23-6	C1•B1•C2•B2 •E2•E1
B6	UMB6N	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=50\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>68;$ $R2/R1=1$	SOT363, SC88	C1•B1•C2•B2 •E2•E1
B7	IMB7A	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_1, 4.7\text{ кОм}$	SOT23-6	C1•B1•C2•B2 •E2•E1
B8	IMB8A	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_1, 10\text{ кОм}$	SOT23-6	C1•B1•C2•B2 •E2•E1
B8	UMB8N	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=100\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $R_1, 10\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•E2•B2 •C2 •B1•C1
B9	EMB9	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=70\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $10\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT563, EMT6	E1•B1•C2 •E2•B2 •C1
B9	IMB9A	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=70\text{ мА}; P_D=300\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $10\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT23-6	C1•B2 •E2•C2 •B1•E1
B9	UMB9N	ROHM	Dnpnp x2	$V_{CC}=50\text{ В}; I_{OUT}=70\text{ мА}; P_D=150\text{ мВт}; h_{21}>100;$ $10\text{ кОм}/47\text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2 •E2•B2 •C1
BAC	ADP3820ART-4.1	AD	chg	Li-Ion; $V_{IN}=4.5...15\text{ В}; V_{OUT}=4.1\text{ В}$	SOT23-6	SD•GND•VOUT•GATE•VIN•IS
BBC	ADP3820ART-4.2	AD	chg	Li-Ion; $V_{IN}=4.5...15\text{ В}; V_{OUT}=4.2\text{ В}$	SOT23-6	SD•GND•VOUT•GATE•VIN•IS
BK	HSMS281K	HP	shd x2	$V_{BR}>20\text{ В}; V_F(I_F=35\text{ мА})<1.0\text{ В};$ $I_R(I_R=15\text{ В})<200\text{ мА}; C_D<1.2\text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1•n.c. A2•K2•n.c. K1
BL	HSMS281L	HP	shd x3	$V_{BR}>20\text{ В}; V_F(I_F=35\text{ мА})<1.0\text{ В};$ $I_R(I_R=15\text{ В})<200\text{ мА}; C_D<1.2\text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1•A2•A3•K3•K2•K1
BL	MBD54DW	ON	shd x2	$V_R<30\text{ В}; V_F(I_F=10\text{ мА})<0.4\text{ В}; C_D<10\text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1•n.c. K2•A2•n.c. K1
C06	DDX123JK	DIODS	Dnpnp/pnp	$V_{CC}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; 2.2\text{ к}/47\text{ к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
C06	DDX123JU	DIODS	Dnpnp/pnp	$V_{CC}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; 2.2\text{ к}/47\text{ к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
C07	DDX143TK	DIODS	Dnpnp/pnp	$V_{CC}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; R_1, 4.7\text{ к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
C07	DDX143TU	DIODS	Dnpnp/pnp	$V_{CC}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; R_1, 4.7\text{ к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
C12	DDX114TK	DIODS	Dnpnp/pnp	$V_{CC}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; R_1, 10\text{ к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
C12	DDX114TU	DIODS	Dnpnp/pnp	$V_{CC}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; R_1, 10\text{ к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
C13	DDX114EK	DIODS	Dnpnp/pnp	$V_{CC}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; 10\text{ к}/10\text{ к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
C13	DDX114EU	DIODS	Dnpnp/pnp	$V_{CC}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; 10\text{ к}/10\text{ к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
C14	DDX114YK	DIODS	Dnpnp/pnp	$V_{CC}=50\text{ В}; I_C=100\text{ мА}; 10\text{ к}/47\text{ к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1

f56 SON-6
M16 USM-6

SOT563
SOT666



SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
C14	DDX114YU	DIODS	Dnprn/pnp	$V_{CC}=50\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; 10\text{ к}/47\text{ к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
C17	DDX124EK	DIODS	Dnprn/pnp	$V_{CC}=50\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; 22\text{ к}/22\text{ к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
C17	DDX124EU	DIODS	Dnprn/pnp	$V_{CC}=50\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; 22\text{ к}/22\text{ к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
C20	DDX144EK	DIODS	Dnprn/pnp	$V_{CC}=50\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; 47\text{ к}/47\text{ к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
C20	DDX144EU	DIODS	Dnprn/pnp	$V_{CC}=50\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; 47\text{ к}/47\text{ к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
C2T	AD7466BRTZ	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD}=1.6...3.6\text{ B}$	SOT23-6	VDD•GND•VIN•SCLK•SDATA•CS
C410	ZXSC410	ZETEX	vcon	$V_{CC}=1.65...8.0\text{ B}; I_{OUT}=300\text{ mA}$	SOT23-6	VCC•GND•STDN•SENSE•VFB•DRIVE
C420	ZXSC420	ZETEX	vcon	$V_{CC}=1.65...8.0\text{ B}; I_{OUT}=300\text{ mA}$	SOT23-6	VCC•GND•EOR•SENSE•VFB•DRIVE
C55	OPA355NA	TI	OA	R-R; $V_{DD}=2.7...5.5\text{ B}; f_{BD}=200\text{ МГц}; I_5=14\text{ mA}; V_{OS}\leq\pm 15\text{ мВ}$	SOT23-6	OUT•V-•+IN•-IN•ENBL•V+
CAA	AD7814ART	AD	dts	10-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD}=2.7...5.5\text{ B}$	SOT23-6	GND•DIN•VDD•SCLK•CS•DOUT
CEW	AD7476AYKS	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD}=2.35...5.25\text{ B}$	SOT363, SC88	VDD•GND•VIN•SCLK•SDATA•CS
CEY	AD7476ABKS	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD}=2.35...5.25\text{ B}$	SOT363, SC88	VDD•GND•VIN•SCLK•SDATA•CS
CEZ	AD7476AAKS	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD}=2.35...5.25\text{ B}$	SOT363, SC88	VDD•GND•VIN•SCLK•SDATA•CS
CFZ	AD7477AAKS	AD	ADC	10-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD}=2.35...5.25\text{ B}$	SOT363, SC88	VDD•GND•VIN•SCLK•SDATA•CS
CHA	AD7414ART	AD	dts	10-паар.; SMBus/I ² C; $V_{DD}=2.7...5.5\text{ B}$	SOT23-6	AS•GND•VDD•SCL•ALERT•SDA
CHB	AD7414ART	AD	dts	10-паар.; SMBus/I ² C; $V_{DD}=2.7...5.5\text{ B}$	SOT23-6	AS•GND•VDD•SCL•ALERT•SDA
CHC	AD7414ART	AD	dts	10-паар.; SMBus/I ² C; $V_{DD}=2.7...5.5\text{ B}$	SOT23-6	AS•GND•VDD•SCL•ALERT•SDA
CHD	AD7414ART	AD	dts	10-паар.; SMBus/I ² C; $V_{DD}=2.7...5.5\text{ B}$	SOT23-6	AS•GND•VDD•SCL•ALERT•SDA
CJZ	AD7478AAKS	AD	ADC	8-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD}=2.35...5.25\text{ B}$	SOT363, SC88	VDD•GND•VIN•SCLK•SDATA•CS
CK	HSMS282K	HP	shd x2	$V_{BR}>15\text{ B}; V_F(I_F=30\text{ mA})<0.7\text{ B}; I_1(V_{R1}=1\text{ B})<100\text{ mA}; C_T<1.0\text{ нФ}; R_0=12\text{ Ом}$	SOT363, SC88	A1•n.c. A2•K2•n.c. K1
CL	HSMS282L	HP	shd x3	$V_{BR}>15\text{ B}; V_F(I_F=30\text{ mA})<0.7\text{ B}; I_1(V_{R1}=1\text{ B})<100\text{ mA}; C_T<1.0\text{ нФ}; R_0=12\text{ Ом}$	SOT363, SC88	A1•A2•A3•K3•K2•K1
CLB	AD7466BRT	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD}=1.6...3.6\text{ B}$	SOT23-6	VDD•GND•VIN•SCLK•SDATA•CS
CMB	AD7467BRT	AD	ADC	10-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD}=1.6...3.6\text{ B}$	SOT23-6	VDD•GND•VIN•SCLK•SDATA•CS
CMU	AD7467BRTZ	AD	ADC	10-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD}=1.6...3.6\text{ B}$	SOT23-6	VDD•GND•VIN•SCLK•SDATA•CS
CNA	AD7466ART	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD}=1.6...3.6\text{ B}$	SOT23-6	VDD•GND•VIN•SCLK•SDATA•CS
CNB	AD7468BRT	AD	ADC	8-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD}=1.6...3.6\text{ B}$	SOT23-6	VDD•GND•VIN•SCLK•SDATA•CS
CNU	AD7468BRTZ	AD	ADC	8-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD}=1.6...3.6\text{ B}$	SOT23-6	VDD•GND•VIN•SCLK•SDATA•CS
cP	μPA873TD	NEC	nprn x2	$V_{BR}=9\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; P_0=230\text{ мВт}; I_{21}=100...145; f_T>3\text{ ГГц}$	M16, 1208	C1•E1•C2•E2•B2•B1
cP	μPA873TS	NEC	nprn x2	$V_{BR}=9\text{ B}; I_C=100\text{ mA}; P_0=230\text{ мВт}; I_{21}=100...145; f_T>3\text{ ГГц}$	SOT666	C1•E1•C2•E2•B2•B1
CP	HSMS282P	HP	shd x4	$V_{BR}>15\text{ B}; V_F(I_F=30\text{ mA})<0.7\text{ B}; I_1(V_{R1}=1\text{ B})<100\text{ mA}; C_T<1.0\text{ нФ}; R_0=12\text{ Ом}$	SOT363, SC88	A1•K1, A2•K2•K3•K4, A3•A4



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типоименал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
COA	AD7680ARJ	AD	ADC	16-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В	SOT23-6	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CQB	AD7680BRJ	AD	ADC	16-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В	SOT23-6	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CUA	AD7920AKS	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.35...5.25$ В	SOT363, SC88	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CUB	AD7920BKS	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.35...5.25$ В	SOT363, SC88	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
CVA	AD7910AKS	AD	ADC	10-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.35...5.25$ В	SOT363, SC88	VDD • GND • VIN • SCLK • SDATA • CS
D1	IMD1A	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $\eta_{21} > 100$; $R_1, 22$ кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D10	IMD10A	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT1} = 500$ мА; $I_{OUT2} = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $\eta_{21} > 68$; 10 кОм/100 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D12	UMD12N	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $\eta_{21} > 68$; 47 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D14	IMD14	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 500$ мА; $P_D = 300$ мВт; $\eta_{21} > 82$; $R2/R1 = 45.5$	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D16	IMD16A	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 500$ мА; $P_D = 300$ мВт; $\eta_{21} > 82$; 2.2 кОм/2.2 кОм; $R_1, 100$ кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D2	EMD2	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 30$ мА; $P_D = 150$ мВт; $\eta_{21} > 56$; 22 кОм/22 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D2	IMD2A	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 30$ мА; $P_D = 300$ мВт; $\eta_{21} > 56$; 22 кОм/22 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D2	UMD2N	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 500$ мА; $P_D = 150$ мВт; $\eta_{21} > 56$; 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D2B	AD5300BRT	AD	DAC	8-паар.; SPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7...5.5$ В	SOT23-6	VOUT • GND • VDD • DIN • SCLK • SYNC
D3	EMD3	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 50$ мА; $P_D = 150$ мВт; $\eta_{21} > 30$; 10 кОм/10 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D3	IMD3A	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 50$ мА; $P_D = 300$ мВт; $\eta_{21} > 30$; 10 кОм/10 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D3	UMD3N	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 50$ мА; $P_D = 150$ мВт; $\eta_{21} > 30$; 10 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D3B	AD5310BRT	AD	DAC	10-паар.; SPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7...5.5$ В	SOT23-6	VOUT • GND • VDD • DIN • SCLK • SYNC
D4B	AD5320BRT	AD	DAC	12-паар.; SPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7...5.5$ В	SOT23-6	VOUT • GND • VDD • DIN • SCLK • SYNC
D6	EMD6	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $\eta_{21} > 100$; $R_1, 4.7$ кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D6	IMD6A	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $\eta_{21} > 100$; $R_1, 4.7$ кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D6	UMD6N	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 100$ мА; $P_D = 150$ мВт; $\eta_{21} > 100$; $R_1, 4.7$ кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D619	ZXTD09N50DE6	ZETEX	nnp x2	$V_{CE} = 50$ В; $I_C = 1$ А; $P_D = 900$ мВт; $\eta_{21} > 20$; $f_t = 215$ МГц	SOT23-6	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
D8	IMD8A	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 100$ мА; $P_D = 300$ мВт; $\eta_{21} > 100$; $R_1, 47$ кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D8B	AD5301BRT	AD	DAC	8-паар.; I ² C; $V_{DD} = 2.7...5.5$ В	SOT23-6	GND • SDA • SCL • VOUT • A0 • VDD
D9	EMD9	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 70$ мА; $P_D = 150$ мВт; $\eta_{21} > 100$; 10 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D9	IMD9A	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 70$ мА; $P_D = 300$ мВт; $\eta_{21} > 100$; 10 кОм/47 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
D9	UMD9N	ROHM	Dnnp/npn	$V_{CC} = 50$ В; $I_{OUT} = 70$ мА; $P_D = 150$ мВт; $\eta_{21} > 100$; 10 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
D9B	AD5311BRT	AD	DAC	10-паар.; I ² C; $V_{DD} = 2.7...5.5$ В	SOT23-6	GND • SDA • SCL • VOUT • A0 • VDD
D9N	AD5320BRTZ	AD	DAC	12-паар.; SPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7...5.5$ В	SOT23-6	VOUT • GND • VDD • DIN • SCLK • SYNC

fS6 SON-6
M16 USM-6SOT563
SOT666SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
DAB	AD5321BRT	AD	DAC	12-разр.; I _С : V _{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-6	GND • SDA • SCL • VOUT • A0 • VDD
F2	RN1903FS	TOSH	Dnnp x2	V _{ср0} = 20 В; I _С = 50 мА; P _D = 50 мВт; R ₁ /R ₂ = 22 кОм/22 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
F3	RN1904FS	TOSH	Dnnp x2	V _{ср0} = 20 В; I _С = 50 мА; P _D = 50 мВт; R ₁ /R ₂ = 47 кОм/47 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
F4	RN1905FS	TOSH	Dnnp x2	V _{ср0} = 20 В; I _С = 50 мА; P _D = 50 мВт; R ₁ /R ₂ = 2.2 кОм/47 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
F5	RN1906FS	TOSH	Dnnp x2	V _{ср0} = 20 В; I _С = 50 мА; P _D = 50 мВт; R ₁ /R ₂ = 4.7 кОм/47 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
F6	RN1907FS	TOSH	Dnnp x2	V _{ср0} = 20 В; I _С = 50 мА; P _D = 50 мВт; R ₁ /R ₂ = 10 кОм/47 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
F7	RN1908FS	TOSH	Dnnp x2	V _{ср0} = 20 В; I _С = 50 мА; P _D = 50 мВт; R ₁ /R ₂ = 22 кОм/47 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
F8	RN1909FS	TOSH	Dnnp x2	V _{ср0} = 20 В; I _С = 50 мА; P _D = 50 мВт; R ₁ /R ₂ = 47 кОм/22 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
F9	RN1910FS	TOSH	Dnnp x2	V _{ср0} = 20 В; I _С = 50 мА; P _D = 50 мВт; R ₁ = 4.7 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
FF	RN1911FS	TOSH	Dnnp x2	V _{ср0} = 20 В; I _С = 50 мА; P _D = 50 мВт; R ₁ = 10 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
FF	RN2971FS	TOSH	Dnnp x2	V _{ср0} = 20 В; I _С = 50 мА; P _D = 50 мВт; R ₁ = 10 кОм	fS6	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
GAAL	REG71050DDC	TI	svcvon	V _{IN} = 1.8...5.5 В; I _{OUT} > 30 мА; V _{OUT} = 5.0 В	TSOT23-6	VOUT • GND • ENBL • CPUMP • VIN • CPUMP+
H0	RN2901FS	TOSH	Dnnp x2	V _{ср0} = 20 В; I _С = 50 мА; P _D = 50 мВт; R ₁ /R ₂ = 4.7 кОм/4.7 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
HOE	AD8063ARTZ	AD	OA	f _{ср0} = 320 МГц; P _D = 75 мВт; V _{DD} = 2.7...8 В	SOT23-6	VOUT • -VS • +IN • -IN • DIS • +VS
H1	EMH1	ROHM	Dnnp x2	V _{ср0} = 50 В; I _С = 30 мА; P _D = 150 мВт; h ₂₁ > 56; 22 кОм/22 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H1	IMH1A	ROHM	Dnnp x2	V _{ср0} = 50 В; I _С = 30 мА; P _D = 300 мВт; h ₂₁ > 56; 22 кОм/22 кОм	SOT23-6	C1 • B1 • B2 • C2 • E2 • E1
H1	RN2902FS	TOSH	Dnnp x2	V _{ср0} = 20 В; I _С = 50 мА; P _D = 50 мВт; R ₁ /R ₂ = 10 кОм/10 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H1	UMH1N	ROHM	Dnnp x2	V _{ср0} = 50 В; I _С = 30 мА; P _D = 150 мВт; h ₂₁ > 56; 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H10	EMH10	ROHM	Dnnp x2	V _{ср0} = 50 В; I _С = 100 мА; P _D = 150 мВт; h ₂₁ > 80; 2.2 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H10	IMH10A	ROHM	Dnnp x2	V _{ср0} = 50 В; I _С = 100 мА; P _D = 300 мВт; h ₂₁ > 80; 2.2 кОм/47 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
H10	UMH10N	ROHM	Dnnp x2	V _{ср0} = 50 В; I _С = 100 мА; P _D = 150 мВт; h ₂₁ > 80; 2.2 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H11	EMH11	ROHM	Dnnp x2	V _{ср0} = 50 В; I _С = 50 мА; P _D = 150 мВт; h ₂₁ > 30; 10 кОм/10 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H11	IMH11A	ROHM	Dnnp x2	V _{ср0} = 50 В; I _С = 50 мА; P _D = 300 мВт; h ₂₁ > 30; 10 кОм/10 кОм	SOT23-6	C1 • B1 • B2 • C2 • E2 • E1
H11	UMH11N	ROHM	Dnnp x2	V _{ср0} = 50 В; I _С = 50 мА; P _D = 150 мВт; h ₂₁ > 30; 10 кОм/10 кОм	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H14	IMH14A	ROHM	Dnnp x2	V _{ср0} = 50 В; I _С = 100 мА; P _D = 300 мВт; h ₂₁ > 100; R1 47 кОм	SOT23-6	C1 • B1 • B2 • C2 • E2 • E1
H14	UMH14N	ROHM	Dnnp x2	V _{ср0} = 50 В; I _С = 100 мА; P _D = 150 мВт; h ₂₁ > 100; R1 47 кОм	SOT363, SC88	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
H14	UMH14N	ROHM	Dnnp x2	V _{ср0} = 50 В; I _С = 100 мА; P _D = 150 мВт; h ₂₁ > 100; R ₁ = 47 кОм	SOT363, SC88	E1 • E2 • B2 • C2 • B1 • C1
H15	IMH15A	ROHM	Dnnp x2	V _{ср0} = 50 В; I _С = 100 мА; P _D = 300 мВт; h ₂₁ > 100; R1 47 кОм	SOT23-6	C1 • B2 • E2 • C2 • B1 • E1
H2	EMH2	ROHM	Dnnp x2	V _{ср0} = 50 В; I _С = 30 мА; P _D = 150 мВт; h ₂₁ > 68; 47 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
H2	IMH2A	ROHM	Dnnp x2	V _{ср0} = 50 В; I _С = 30 мА; P _D = 300 мВт; h ₂₁ > 68; 47 кОм/47 кОм	SOT23-6	C1 • B1 • B2 • C2 • E2 • E1
H2	RN2903FS	TOSH	Dnnp x2	V _{ср0} = 20 В; I _С = 50 мА; P _D = 50 мВт; R ₁ /R ₂ = 22 кОм/22 кОм	fS6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
H2	UMH2N	ROHM	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 30\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ 47 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	C1•B1•B2•C2•E2•E1
H3	EMH3	ROHM	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 100;$ R1 4,7 кОм	SOT563, EMT6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H3	IMH3A	ROHM	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 100;$ R1 4,7 кОм	SOT23-6	C1•B1•B2•C2•E2•E1
H3	RN2904FS	TOSH	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ R1/R2 = 47 кОм/47 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H3	UMH3N	ROHM	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 100;$ R1 4,7 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H4	IMH4A	ROHM	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 100;$ R1 10 кОм	SOT23-6	C1•B2•E2•C2•B1•E1
H4	RN2905FS	TOSH	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ R1/R2 = 2,2 кОм/47 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H4	UMH4N	ROHM	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 100;$ R1 10 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H5	IMH5A	ROHM	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 30\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ 22 кОм/22 кОм	SOT23-6	C1•B1•C2•B2•E2•E1
H5	MBD770DW	ON	shd x2	$V_R < 70\text{ В}; V_F (I_F = 10\text{ мА}) < 1\text{ В}; C_0 < 1\text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1•n. c. •K2•A2•n. c. •K1
H5	RN2906FS	TOSH	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ R1/R2 = 4,7 кОм/47 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H5	UMH5N	ROHM	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 30\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 56;$ 22 кОм/22 кОм	SOT363, SC88	C1•B1•C2•B2•E2•E1
H6	IMH6A	ROHM	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{OUT} = 30\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ R2/R1 = 1	SOT23-6	C1•B1•C2•B2•E2•E1
H6	RN2907FS	TOSH	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ R1/R2 = 10 кОм/47 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H6	UMH6N	ROHM	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{OUT} = 30\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ R2/R1 = 1	SOT363, SC88	C1•B1•C2•B2•E2•E1
H6B	AD8029AKS	AD	OA	$f_{BD} = 120\text{ МГц}; P_D = 18\text{ мВт}; V_{DD} = 2,7...1,2\text{ В}$	SOT363, SC88	VOUT•-VS•+IN•-IN•DIS•+VS
H7	RN2908FS	TOSH	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ R1/R2 = 22 кОм/47 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H8	IMH8A	ROHM	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 100;$ R1 10 кОм	SOT23-6	C1•B1•C2•B2•E2•E1
H8	RN2909FS	TOSH	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ R1/R2 = 47 кОм/22 кОм	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H8	UMH8N	ROHM	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 100;$ R1 10 кОм	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
H9	EMH9	ROHM	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{OUT} = 70\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ 10 кОм/47 кОм	SOT563, EMT6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H9	IMH9A	ROHM	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{OUT} = 70\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ 10 кОм/47 кОм	SOT23-6	C1•B1•E2•C2•B1•E1
H9	RN2910FS	TOSH	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт}; R_1 = 4,7\text{ кОм}$	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
H9	UMH9N	ROHM	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}; I_{OUT} = 70\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 68;$ 10 кОм/47 кОм	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
HF	RN2911FS	TOSH	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт}; R_1 = 10\text{ кОм}$	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
HH	HSMS282M	HP	shd x4	$V_{BR} > 15\text{ В}; V_F (I_F = 30\text{ мА}) < 0,7\text{ В};$ $I_R (V_R = 1\text{ В}) < 100\text{ нА}; C_c < 1,0\text{ нФ}; R_b = 12\text{ Ом}$	SOT363, SC88	A1•K1, K2, K3, K4•A2•A3•K1, K2, K3, K4•A4
HHA	AD8063ART	AD	OA	$f_{BD} = 320\text{ МГц}; P_D = 75\text{ мВт}; V_{DD} = 2,7...8\text{ В}$	SOT23-6	VOUT•-VS•+IN•-IN•DIS•+VS
J0	RN1961FS	TOSH	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ R1/R2 = 4,7 кОм/4,7 кОм	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
J1	RN1962FS	TOSH	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ R1/R2 = 10 кОм/10 кОм	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
J2	RN1963FS	TOSH	Dnnpn x2	$V_{CE0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ R1/R2 = 22 кОм/22 кОм	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1

fS6 SON-6
M16 USM-6SOT563
SOT666SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
J3	RN1964FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 47\text{ К}\Omega/47\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
J3A	AD8361ART	AD	PD	$f_{BD} < 2.5\text{ ГГц}; P_D = 12\text{ мВт}; V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-6	VRMS•COMM•FLTR•PWND• RFIN•VPOS
J4	RN1965FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 2.2\text{ К}\Omega/47\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
J5	RN1966FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 4.7\text{ К}\Omega/47\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
J6	RN1967FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 10\text{ К}\Omega/47\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
J7	RN1968FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 22\text{ К}\Omega/47\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
J8	RN1969FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 47\text{ К}\Omega/22\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
J9	RN1901FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 4.7\text{ К}\Omega/4.7\text{ К}\Omega$	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
J9	RN1970FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт}; R_1 = 4.7\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
JF	RN1902FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 10\text{ К}\Omega/10\text{ К}\Omega$	fS6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
JF	RN1971FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт}; R_1 = 10\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
JH	RN1972FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт}; R_1 = 22\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
JJ	RN1973FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт}; R_1 = 47\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
JSs	BAS21U	INF	di x3	$V_A < 200\text{ В}; I_C < 250\text{ мА}; V_f (I_f = 100\text{ мА}) < 1.0\text{ В};$ $I_B < 0.1\text{ мкА}$	SOT457, SC74	A1•A2•A3•K3•K2•K1
K0	RN2961FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 4.7\text{ К}\Omega/4.7\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
K1	RN2962FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 10\text{ К}\Omega/10\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
K1	UM6K1N	ROHM	nMOS x2	$V_{DS} = 30\text{ В}; I_D = 100\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт};$ $R_{\theta DS(amb)} < 13\text{ К}\Omega$	SOT363, SC88	S1•G1•D2•S2•G2•D1
K2	RN2963FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 22\text{ К}\Omega/22\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
K3	RN2964FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 47\text{ К}\Omega/47\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
K4	RN2965FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 2.2\text{ К}\Omega/47\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
K5	RN2966FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 4.7\text{ К}\Omega/47\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
K6	RN2967FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 10\text{ К}\Omega/47\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
K7	NCP802SAN5T1	ON	batprot	$V_{CC} = 1.5...5\text{ В}; V_{TH(DU)} = 4.275\text{ В}$	SON-6	DO•Vcell•GND•DS•CO•P
K7	RN2968FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 22\text{ К}\Omega/47\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
K7P	BC847PN	DIODS	npnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт};$ $I_{T21} = 200...475; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
K8	RN2969FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт};$ $R_{\theta J/R_2} = 47\text{ К}\Omega/22\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
K9	RN2970FS	TOSH	Dnnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 50\text{ мВт}; R_1 = 4.7\text{ К}\Omega$	fS6	E1•E2•B2•C2•B1•C1
KC1	MMBZ5221BS	DIODS	dz x2	$V_Z (I_{ZT} = 20\text{ мА}) = 2.28...2.52\text{ В}; I_R < 100\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.•K2•A2•n.c.•K1
KC3	MMBZ5223BS	DIODS	dz x2	$V_Z (I_{ZT} = 20\text{ мА}) = 2.57...2.84\text{ В}; I_R < 75\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.•K2•A2•n.c.•K1
KC5	MMBZ5225BS	DIODS	dz x2	$V_Z (I_{ZT} = 20\text{ мА}) = 2.85...3.15\text{ В}; I_R < 50\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.•K2•A2•n.c.•K1
KD	NCP802SAN6T1	ON	batprot	$V_{CC} = 1.5...5\text{ В}; V_{TH(DU)} = 4.28\text{ В}$	SON-6	DO•Vcell•GND•DS•CO•P
KE1	MMBZ5231BS	DIODS	dz x2	$V_Z (I_{ZT} = 20\text{ мА}) = 4.85...5.36\text{ В}; I_R < 5\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.•K2•A2•n.c.•K1



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
KE2	MMBZ5232BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=5.32...5.88\text{ В}; I_{\text{H}} < 5\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.•K2•A2•n.c.•K1
KE3	MMBZ5233BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=5.70...6.30\text{ В}; I_{\text{H}} < 5\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.•K2•A2•n.c.•K1
KE4	MMBZ5234BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=5.89...6.51\text{ В}; I_{\text{H}} < 5\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.•K2•A2•n.c.•K1
KE5	MMBZ5235BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=6.46...7.14\text{ В}; I_{\text{H}} < 3\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.•K2•A2•n.c.•K1
KF1	MMBZ5236BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=7.13...7.88\text{ В}; I_{\text{H}} < 3\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KF2	MMBZ5237BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=7.79...8.61\text{ В}; I_{\text{H}} < 3\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KF3	MMBZ5238BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=8.27...9.14\text{ В}; I_{\text{H}} < 3\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KF4	MMBZ5239BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=8.65...9.56\text{ В}; I_{\text{H}} < 3\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KF5	MMBZ5240BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=9.5...10.5\text{ В}; I_{\text{H}} < 3\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KG1	MMBZ5226BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=3.14...3.47\text{ В}; I_{\text{H}} < 25\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KG2	MMBZ5227BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=3.42...3.78\text{ В}; I_{\text{H}} < 15\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KG3	MMBZ5228BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=3.71...4.10\text{ В}; I_{\text{H}} < 10\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KG4	MMBZ5229BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=4.09...4.52\text{ В}; I_{\text{H}} < 5\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KG5	MMBZ5230BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=4.47...4.94\text{ В}; I_{\text{H}} < 5\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
kH	μPA891TD	NEC	nnp x2	$V_{\text{CBQ}}=9\text{ В}; I_{\text{C}}=100\text{ mA}; P_{\text{D}}=230\text{ мВт};$ $h_{21}=100...160; f_{\text{T}} > 3.5\text{ ГГц}$	M16, 1208	C1•E1•C2•B2•E2•B1
KH1	MMBZ5241BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=10.45...11.55\text{ В}; I_{\text{H}} < 2\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KH2	MMBZ5242BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=20\text{ mA})=11.4...12.6\text{ В}; I_{\text{H}} < 1\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KH3	MMBZ5243BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=9.5\text{ mA})=12.35...13.65\text{ В}; I_{\text{H}} < 0.5\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KH5	MMBZ5245BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=8.5\text{ mA})=14.25...15.75\text{ В}; I_{\text{H}} < 0.1\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KJ1	MMBZ5246BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=7.8\text{ mA})=15.2...16.8\text{ В}; I_{\text{H}} < 0.1\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KJ3	MMBZ5248BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=7.0\text{ mA})=17.1...18.9\text{ В}; I_{\text{H}} < 0.1\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KJ5	MMBZ5250BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=6.2\text{ mA})=19.0...21.0\text{ В}; I_{\text{H}} < 0.1\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KK1	MMBZ5251BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=5.6\text{ mA})=20.9...23.1\text{ В}; I_{\text{H}} < 0.1\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KK2	MMBZ5252BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=5.2\text{ mA})=22.8...25.2\text{ В}; I_{\text{H}} < 0.1\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KK4	MMBZ5254BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=5.0\text{ mA})=25.65...28.35\text{ В}; I_{\text{H}} < 0.1\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KK5	MMBZ5255BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=4.5\text{ mA})=26.6...29.4\text{ В}; I_{\text{H}} < 0.1\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
kL	μPA828TD	NEC	nnp x2	$V_{\text{CBQ}}=5\text{ В}; I_{\text{C}}=30\text{ mA}; P_{\text{D}}=180\text{ мВт}; h_{21}=70...140;$ $f_{\text{T}} > 7\text{ ГГц}$	M16, 1208	C1•E1•C2•B2•E2•B1
KM1	MMBZ5256BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=4.2\text{ mA})=28.5...31.5\text{ В}; I_{\text{H}} < 0.1\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1
KM2	MMBZ5257BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{ZT}=3.8\text{ mA})=31.35...34.65\text{ В}; I_{\text{H}} < 0.1\text{ мкА}$	SOT363, SC88	A1•n.c.~K2•A2•n.c.~K1

fS6 SON-6
M16 USM-6SOT563
SOT666SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3*4*5*6
KM3	MMBZ5258BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{TZ}=3.4\text{ mA})=34.2...37.8\text{ B}$; $I_R < 0.1\text{ mA}$	SOT363, SC88	A1 • n. c. • K2 • A2 • n. c. • K1
KM4	MMBZ5259BS	DIODS	dz x2	$V_Z(I_{TZ}=3.2\text{ mA})=37.05...41.0\text{ B}$; $I_R < 0.1\text{ mA}$	SOT363, SC88	A1 • n. c. • K2 • A2 • n. c. • K1
kN	μPA892TD	NEC	nnp x2	$V_{CE0}=15\text{ B}$; $I_C=35\text{ mA}$; $P_D=210\text{ mBt}$; $h_{21}=50...100$; $f_T > 18\text{ ГГц}$	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
KN	NCP802SAN1T1	ON	batprot	$V_{CC}=1.5...5\text{ B}$; $V_{TROU}=4.35\text{ B}$	SON-6	DO • Vcell • GND • DS • CO • P
KN	NCP802SNT1T1	ON	batprot	$V_{CC}=1.5...5\text{ B}$; $V_{TROU}=4.35\text{ B}$	SOT23-6	DO • P • CO • DS • Vcell • GND
kP	μPA895TD	NEC	nnp x2	$V_{CE0}=9\text{ B}$; $I_C=100\text{ mA}$; $P_D=210\text{ mBt}$; $h_{21}=100...145$; $f_T > 3\text{ ГГц}$	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
kP	μPA895TS	NEC	nnp x2	$V_{CE0}=9\text{ B}$; $I_C=100\text{ mA}$; $P_D=210\text{ mBt}$; $h_{21}=100...145$; $f_T > 3\text{ ГГц}$	SOT666	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
L1B	ADP3330ART-2.5	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.9...12\text{ B}$; $I_{OUT}=200\text{ mA}$; $V_{OUT}=2.5\text{ B}$	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • NR • SD
L2B	ADP3330ART-2.75	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.9...12\text{ B}$; $I_{OUT}=200\text{ mA}$; $V_{OUT}=2.75\text{ B}$	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • NR • SD
L3B	ADP3330ART-2.85	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.9...12\text{ B}$; $I_{OUT}=200\text{ mA}$; $V_{OUT}=2.85\text{ B}$	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • NR • SD
L4B	ADP3330ART-3	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.9...12\text{ B}$; $I_{OUT}=200\text{ mA}$; $V_{OUT}=3\text{ B}$	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • NR • SD
L5B	ADP3330ART-3.3	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.9...12\text{ B}$; $I_{OUT}=200\text{ mA}$; $V_{OUT}=3.3\text{ B}$	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • NR • SD
L6B	ADP3330ART-3.6	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.9...12\text{ B}$; $I_{OUT}=200\text{ mA}$; $V_{OUT}=3.6\text{ B}$	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • NR • SD
L8B	ADP3330ART-5	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.9...12\text{ B}$; $I_{OUT}=200\text{ mA}$; $V_{OUT}=5\text{ B}$	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • NR • SD
L9B	ADP3331ART	AD	reg	LDO; $V_{IN}=2.6...12\text{ B}$; $I_{OUT}=200\text{ mA}$; $V_{OUT}=1.5...11.75\text{ B}$	SOT23-6	OUT • IN • ERR • GND • FB • SD
LAB	ADP3300ART-2.7	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12\text{ B}$; $I_{OUT}=50\text{ mA}$; $V_{OUT}=2.7\text{ B}$	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LBB	ADP3300ART-3	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12\text{ B}$; $I_{OUT}=50\text{ mA}$; $V_{OUT}=3\text{ B}$	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LCB	ADP3300ART-3.2	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12\text{ B}$; $I_{OUT}=50\text{ mA}$; $V_{OUT}=3.2\text{ B}$	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LDB	ADP3300ART-3.3	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12\text{ B}$; $I_{OUT}=50\text{ mA}$; $V_{OUT}=3.3\text{ B}$	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LEB	ADP3300ART-5	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12\text{ B}$; $I_{OUT}=50\text{ mA}$; $V_{OUT}=5\text{ B}$	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LFB	ADP3300ART-2.85	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12\text{ B}$; $I_{OUT}=50\text{ mA}$; $V_{OUT}=2.85\text{ B}$	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LTC	ADP3307ART-2.7	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12\text{ B}$; $I_{OUT}=100\text{ mA}$; $V_{OUT}=2.7\text{ B}$	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LUC	ADP3307ART-3	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12\text{ B}$; $I_{OUT}=100\text{ mA}$; $V_{OUT}=3\text{ B}$	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LVC	ADP3307ART-3.2	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12\text{ B}$; $I_{OUT}=100\text{ mA}$; $V_{OUT}=3.2\text{ B}$	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LWC	ADP3307ART-3.3	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12\text{ B}$; $I_{OUT}=100\text{ mA}$; $V_{OUT}=3.3\text{ B}$	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
LXC	ADP3307ART-2.85	AD	reg	LDO; $V_{IN}=3...12\text{ B}$; $I_{OUT}=100\text{ mA}$; $V_{OUT}=2.85\text{ B}$	SOT23-6	GND • NR • SD • OUT • IN • ERR
M4	MBD110DW	ON	shd x2	$V_A < 7\text{ B}$; $V_E(I_E=10\text{ mA}) < 0.6\text{ B}$; $C_D < 1\text{ nF}$	SOT363, SC88	A1 • n. c. • K2 • A2 • n. c. • K1
MA	MBT3904DW1	ON	nnp x2	$V_{CE0}=60\text{ B}$; $I_C=200\text{ mA}$; $P_D=150\text{ mBt}$; $h_{21} > 30$; $f_T > 300\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E2 • B2 • C1 • E1 • B1 • C2
MCs	BFS17S	SIEM	nnp x2	$V_{CE0}=25\text{ B}$; $I_C=50\text{ mA}$; $P_D=280\text{ mBt}$; $h_{21}=20...150$; $f_T > 2500\text{ МГц}$	SOT363, SC88	B1 • E1 • C2 • B2 • E2 • C1
MJ	MBT3904DW2	ON	nnp x2	$V_{CE0}=60\text{ B}$; $I_C=200\text{ mA}$; $P_D=150\text{ mBt}$; $h_{21} > 30$; $f_T > 300\text{ МГц}$	SOT363, SC88	B2 • B1 • C1 • E1 • E2 • C2
MMO	ADM8828ART	AD	dc/dc	$V_{IN}=1.5...5.5\text{ B}$; $I_{OUT} > 25\text{ mA}$; $V_{OUT}=-1.5...-5.5\text{ B}$; $I_{CC} < 1\text{ mA}$	SOT23-6	OUT • IN • CAP- • GND • SHDN • CAP+
MNO	ADM8829ART	AD	dc/dc	$V_{IN}=1.5...5.5\text{ B}$; $I_{OUT} > 25\text{ mA}$; $V_{OUT}=-1.5...-5.5\text{ B}$; $I_{CC} < 1\text{ mA}$	SOT23-6	OUT • IN • CAP- • GND • n. c. • CAP+
N06	DDC123JK	DIODS	Dnnp x2	$V_{CC}=50\text{ B}$; $I_C=100\text{ mA}$; $2.2\text{ k}/47\text{ k}$	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N06	DDC123JU	DIODS	Dnnp x2	$V_{CC}=50\text{ B}$; $I_C=100\text{ mA}$; $2.2\text{ k}/47\text{ k}$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N07	DDC143TK	DIODS	Dnnp x2	$V_{CC}=50\text{ B}$; $I_C=100\text{ mA}$; $R_1, 4.7\text{ k}$	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N07	DDC143TU	DIODS	Dnnp x2	$V_{CC}=50\text{ B}$; $I_C=100\text{ mA}$; $R_1, 4.7\text{ k}$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
N12	DDC114TK	DIODS	Dnnp x2	$V_{CC}=50\text{ B}$; $I_C=100\text{ mA}$; $R_1, 10\text{ k}$	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
N12	DDC114TU	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; R_1, 10\text{к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
N13	DDC114EK	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 10\text{к}/10\text{к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
N13	DDC114EU	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 10\text{к}/10\text{к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
N14	DDC114YK	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 10\text{к}/47\text{к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
N14	DDC114YU	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 10\text{к}/47\text{к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
N17	DDC124EK	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 22\text{к}/22\text{к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
N17	DDC124EU	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 22\text{к}/22\text{к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
N20	DDC144EK	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 47\text{к}/47\text{к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
N20	DDC144EU	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 47\text{к}/47\text{к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
NN	HSMS282N	HP	shd x4	$V_{BR} > 15\text{В}; V_F (I_F = 30\text{мА}) < 0.7\text{В}; I_R (V_R = 1\text{В}) < 100\text{нА}; C_T < 1.0\text{нФ}; R_0 = 12\text{Ом}$	SOT363, SC88	K1•A1, A2, A3, A4•K2•K3•A1, A2, A3, A4•K4
nQ	μPA841TD	NEC	npnx2	$V_{DS} = 9\text{В}; I_C = 30\text{мА}; I_{C2} = 100\text{мА}; P_D = 210\text{мВт}; f_{T1} > 10\text{ГГц}; f_{T2} > 3.5\text{ГГц}$	M16, 1208	C1•E1•C2•B2•E2•B1
O	HSMS280R	HP	shd x4	$V_{BR} > 70\text{В}; V_F (I_F = 15\text{мА}) < 1.0\text{В}; I_R (V_R = 50\text{В}) < 200\text{нА}; C_T < 2.0\text{нФ}$	SOT363, SC88	K1•A1, K2•A2•K3•A3, K4•A4
OO	HSMS282R	HP	shd x4	$V_{BR} > 15\text{В}; V_F (I_F = 30\text{мА}) < 0.7\text{В}; I_R (V_R = 1\text{В}) < 100\text{нА}; C_T < 1.0\text{нФ}; R_0 = 12\text{Ом}$	SOT363, SC88	K1•A1, K2•A2•K3•A3, K4•A4
P06	DDA123JK	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 2.2\text{к}/47\text{к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
P06	DDA123JU	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 2.2\text{к}/47\text{к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
P07	DDA143TK	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; R_1, 4.7\text{к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
P07	DDA143TU	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; R_1, 4.7\text{к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
P12	DDA114TK	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; R_1, 10\text{к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
P12	DDA114TU	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; R_1, 10\text{к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
P13	DDA114EK	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 10\text{к}/10\text{к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
P13	DDA114EU	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 10\text{к}/10\text{к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
P14	DDA114YK	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 10\text{к}/47\text{к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
P14	DDA114YU	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 10\text{к}/47\text{к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
P17	DDC124EK	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 22\text{к}/22\text{к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
P17	DDC124EU	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 22\text{к}/22\text{к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
P20	DDA144EK	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 47\text{к}/47\text{к}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
P20	DDA144EU	DIODS	Dnpnx2	$V_{CC}=50\text{В}; I_C=100\text{мА}; 47\text{к}/47\text{к}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
PGs	BGA428	INF	amp	$V_{CC}=2.4...3\text{В}; I_{CC}=8.2\text{мА}; G_{Mk}=20\text{дБ} (f_1=1\text{ГГц})$	SOT363, SC88	VD•GND•OUT•GS•GND•IN
PL	HSMS285L	HP	shd x3	$V_F (I_F = 1\text{мА}) < 0.25\text{В}; C_T = 0.3\text{нФ}$	SOT363, SC88	A1•A2•A3•K3•K2•K1
PP	HSMS285P	HP	shd x4	$V_F (I_F = 1\text{мА}) < 0.25\text{В}; C_T = 0.3\text{нФ}$	SOT363, SC88	A1•K1, A2•K2•K3•K4, A3•A4
R10B	REG710NA-5	TI	scvcon	$V_{IN}=1.8...5.5\text{В}; I_{OUT}>30\text{мА}; V_{OUT}=5.0\text{В}$	SOT23-6	VOUT•GND•Enable•CPUMP•VIN•CPUMP+
R10C	REG710NA-3.3	TI	scvcon	$V_{IN}=1.8...5.5\text{В}; I_{OUT}>30\text{мА}; V_{OUT}=3.3\text{В}$	SOT23-6	VOUT•GND•Enable•CPUMP•VIN•CPUMP+
R10D	REG710NA-3	TI	scvcon	$V_{IN}=1.8...5.5\text{В}; I_{OUT}>30\text{мА}; V_{OUT}=3.0\text{В}$	SOT23-6	VOUT•GND•Enable•CPUMP•VIN•CPUMP+
R10F	REG710NA-2.7	TI	scvcon	$V_{IN}=1.8...5.5\text{В}; I_{OUT}>30\text{мА}; V_{OUT}=2.7\text{В}$	SOT23-6	VOUT•GND•Enable•CPUMP•VIN•CPUMP+

f56 SON-6
M16 USM-6SOT563
SOT666SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
R10G	REG710NA-2.5	TI	scvcon	$V_{IN} = 1.8...5.5 В$; $I_{OUT} > 30 мА$; $V_{OUT} = 2.5 В$	SOT23-6	VOUT • GND • Enable • CPUMP • VIN • CPUMP+
R10H	REG7105SDCC	TI	scvcon	$V_{IN} = 1.8...5.5 В$; $I_{OUT} > 30 мА$; $V_{OUT} = 5.5 В$	TSOT23-6	VOUT • GND • Enable • CPUMP • VIN • CPUMP+
R24	μPA801TFB	NEC	npn x2	$V_{CBO} = 20 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 230 мВт$; $I_{h21} = 70...140$; $f_T > 3 ГГц$	SOT363, SC88	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
R25	μPA801TGB	NEC	npn x2	$V_{CBO} = 20 В$; $I_C = 100 мА$; $P_D = 230 мВт$; $I_{h21} = 125...250$; $f_T > 3 ГГц$	SOT363, SC88	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
R34	μPA802TFB	NEC	npn x2	$V_{CBO} = 20 В$; $I_C = 65 мА$; $P_D = 200 мВт$; $I_{h21} = 70...150$; $f_T > 4.5 ГГц$	SOT363, SC88	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
R35	μPA802TGB	NEC	npn x2	$V_{CBO} = 20 В$; $I_C = 65 мА$; $P_D = 200 мВт$; $I_{h21} = 110...240$; $f_T > 4.5 ГГц$	SOT363, SC88	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
R84	μPA827TF	NEC	npn x2	$V_{CBO} = 5 В$; $I_C = 10 мА$; $P_D = 60 мВт$; $I_{h21} = 70...140$; $f_T > 8.5 ГГц$	TSOT363	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
R86	μPA828TF	NEC	npn x2	$V_{CBO} = 5 В$; $I_C = 30 мА$; $P_D = 180 мВт$; $I_{h21} = 70...140$; $f_T > 7 ГГц$	TSOT363	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
REs	BFS480	SIEM	npn x2	$V_{CBO} = 10 В$; $I_C = 10 мА$; $P_D = 80 мВт$; $I_{h21} = 30...200$; $f_T = 7500 МГц$	SOT363, SC88	B1 • E1 • C2 • B2 • E2 • C1
RFs	BFS481	SIEM	npn x2	$V_{CBO} = 20 В$; $I_C = 20 мА$; $P_D = 150 мВт$; $I_{h21} = 50...200$; $f_T = 8000 МГц$	SOT363, SC88	B1 • E1 • C2 • B2 • E2 • C1
RGs	BFS482	SIEM	npn x2	$V_{CBO} = 20 В$; $I_C = 35 мА$; $P_D = 250 мВт$; $I_{h21} = 50...200$; $f_T = 8000 МГц$	SOT363, SC88	B1 • E1 • C2 • B2 • E2 • C1
RHs	BFS483	SIEM	npn x2	$V_{CBO} = 20 В$; $I_C = 65 мА$; $P_D = 450 мВт$; $I_{h21} = 50...200$; $f_T = 8000 МГц$	SOT363, SC88	B1 • E1 • C2 • B2 • E2 • C1
RL	μPA800T	NEC	npn x2	$V_{CBO} = 20 В$; $I_C = 35 мА$; $P_D = 200 мВт$; $I_{h21} = 80...200$; $f_T > 5.5 ГГц$	SOT363, SC88	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
RL	μPA800TF	NEC	npn x2	$V_{CBO} = 20 В$; $I_C = 35 мА$; $P_D = 200 мВт$; $I_{h21} = 80...200$; $f_T > 5.5 ГГц$	TSOT363	C1 • E1 • C2 • E2 • B2 • B1
S00	ADG741BKSZ	AD	asw	2xSPST; $R_{ON} < 4 Ом$; $V_{DD} = 1.8...5.5 В$	SOT363, SC88	D • S • GND • IN • n. c. • VDD
S01	ADG742BKSZ	AD	asw	2xSPST; $R_{ON} < 4 Ом$; $V_{DD} = 1.8...5.5 В$	SOT363, SC88	D • S • GND • IN • n. c. • VDD
S0M	ADG779BKSZ	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 6 Ом$; $V_{DD} = 1.8...5.5 В$	SOT363, SC88	IN • VDD • GND • S1 • D • S2
S18	ADG602BRTZ	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 5.5 Ом$; $V_{DD} = 2.7...5.5 / ± 2.7...± 5.5 В$	SOT23-6	VDD • S • VSS • GND • D • IN
s1A	SMBT33904S	SIEM	npn x2	$V_{CBO} = 60 В$; $I_C = 200 мА$; $P_D = 250 мВт$; $I_{h21} = 100...300$; $f_T > 300 МГц$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
s1A	SMBT33904U	SIEM	npn x2	$V_{CBO} = 60 В$; $I_C = 200 мА$; $P_D = 250 мВт$; $I_{h21} = 100...300$; $f_T > 300 МГц$	SOT457, SC74	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
S1B	ADG465BRT	AD	prot	$V_{PR0T} < ± 40 В$; $V_{DD} = ± 15 В$	SOT23-6	VD1 • n. c. • VSS • VS1 • n. c. • VDD
s2A	SMBT33906S	SIEM	npn x2	$V_{CBO} = 40 В$; $I_C = 200 мА$; $P_D = 250 мВт$; $I_{h21} = 100...300$; $f_T > 250 МГц$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
s2A	SMBT33906U	SIEM	npn x2	$V_{CBO} = 40 В$; $I_C = 200 мА$; $P_D = 250 мВт$; $I_{h21} = 100...300$; $f_T > 250 МГц$	SOT457, SC74	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
S3B	ADG701BRT	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 4 Ом$; $V_{DD} = 1.8...5.5 В$	SOT23-6	D • S • GND • IN • n. c. • VDD
s3P	SMBT33904PN	SIEM	npn/npn	$V_{CBO} = 40 В$; $I_C = 200 мА$; $P_D = 250 мВт$; $I_{h21} = 100...300$; $f_T > 250 МГц$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
S4B	ADG702BRT	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 4 Ом$; $V_{DD} = 1.8...5.5 В$	SOT23-6	D • S • GND • IN • n. c. • VDD
S5B	ADG719BRT	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 7 Ом$; $V_{DD} = 1.8...5.5 В$	SOT23-6	IN • VDD • GND • S1 • D • S2
SDA	ADG751ART	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 40 Ом$; $V_{DD} = 1.8...5.5 В$	SOT23-6	S • VDD • n. c. • IN • GND • D
SDB	ADG751BRT	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 40 Ом$; $V_{DD} = 1.8...5.5 В$	SOT23-6	S • VDD • n. c. • IN • GND • D
SEB	ADG752BRT	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 20 Ом$; $V_{DD} = 1.8...5.5 В$	SOT23-6	D • VDD • S1 • IN • GND • S2
SFB	ADG741BKS	AD	asw	2xSPST; $R_{ON} < 4 Ом$; $V_{DD} = 1.8...5.5 В$	SOT363, SC88	D • S • GND • IN • n. c. • VDD
SGB	ADG742BKS	AD	asw	2xSPST; $R_{ON} < 4 Ом$; $V_{DD} = 1.8...5.5 В$	SOT363, SC88	D • S • GND • IN • n. c. • VDD



SOT23-6 **SOT457** **SOT363**
TSOT23-6 **MW-6** **TSOT363**



SOT563 **SON-6** **fS6**
SOT666 **USM-6** **M16**

Код	Типоименал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
SHB	ADG749BKS	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 7 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8...5.5 \text{ В}$	SOT363, SC88	IN•VDD•GND•S1•D•S2
SKB	ADG779BKS	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 6 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8...5.5 \text{ В}$	SOT363, SC88	IN•VDD•GND•S1•D•S2
SLB	ADG801BRT	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 0.4 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8...5.5 \text{ В}$	SOT23-6	D•S•GND•IN•n.c.•VDD
SMB	ADG802BRT	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 0.4 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8...5.5 \text{ В}$	SOT23-6	D•S•GND•IN•n.c.•VDD
SNB	ADG819BRT	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 0.8 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8...5.5 \text{ В}$	SOT23-6	IN•VDD•GND•S1•D•S2
SPB	ADG820BRT	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 0.8 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8...5.5 \text{ В}$	SOT23-6	IN•VDD•GND•S1•D•S2
STB	ADG601BRT	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 5.5 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 2.7...5.5/\pm 2.7...5.5 \text{ В}$	SOT23-6	VDD•S•VSS•GND•D•IN
STB#	ADG601BRTZ	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 5.5 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 2.7...5.5/\pm 2.7...5.5 \text{ В}$	SOT23-6	VDD•S•VSS•GND•D•IN
SUB	ADG602BRT	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 5.5 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 2.7...5.5/\pm 2.7...5.5 \text{ В}$	SOT23-6	VDD•S•VSS•GND•D•IN
T1	EMT1	ROHM	pnnp x2	$V_{CBO} = 60 \text{ В}$; $I_C = 150 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} > 120$	SOT563, EMT6	E1•B1•C2 • E2•B2•C1
T1	IMT1A	ROHM	pnnp x2	$V_{CBO} = 60 \text{ В}$; $I_C = 150 \text{ mA}$; $P_D = 300 \text{ мВт}$; $h_{21} > 120$	SOT23-6	C1•B1•E2•C2 • B1•E1
T1	UMT1N	ROHM	pnnp x2	$V_{CBO} = 50 \text{ В}$; $I_C = 100 \text{ mA}$; $P_D (\text{com.}) = 300 \text{ мВт}$; $h_{21} > 120$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
T17	IMT17	ROHM	pnnp x2	$V_{CBO} = 60 \text{ В}$; $I_C = 500 \text{ mA}$; $P_D = 300 \text{ мВт}$; $h_{21} > 120$	SOT23-6	C1•B2•E2•C2 • B1•E1
T1H	ADT7301ARTZ	AD	dts	13-паар.; SPI/OSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7...5.25 \text{ В}$	SOT23-6	GND•DIN•VDD•SCLK•CS•DOUT
T2	EMT2	ROHM	pnnp x2	$V_{CBO} = 60 \text{ В}$; $I_C = 150 \text{ mA}$; $P_D = 300 \text{ мВт}$; $h_{21} > 100$	SOT563, EMT6	E2•E1•B1•C1•B2•C2
T2	IMT2A	ROHM	pnnp x2	$V_{CBO} = 60 \text{ В}$; $I_C = 150 \text{ mA}$; $P_D = 300 \text{ мВт}$; $h_{21} > 100$	SOT23-6	C2•B2•C1•B1•E1•E2
T2	UMT2N	ROHM	pnnp x2	$V_{CBO} = 50 \text{ В}$; $I_C = 100 \text{ mA}$; $P_D (\text{com.}) = 300 \text{ мВт}$; $h_{21} > 120$	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
T3	EMT3	ROHM	pnnp x2	$V_{CBO} = 60 \text{ В}$; $I_C = 150 \text{ mA}$; $P_D = 150 \text{ мВт}$; $h_{21} > 100$	SOT563, EMT6	E2•B2•B1•C1•E1•C2
T3	IMT3A	ROHM	pnnp x2	$V_{CBO} = 60 \text{ В}$; $I_C = 150 \text{ mA}$; $P_D = 300 \text{ мВт}$; $h_{21} > 100$	SOT457, SC74	C2•E1•C1•B1•B2•E2
T3	UMT3N	ROHM	pnnp x2	$V_{CBO} = 50 \text{ В}$; $I_C = 100 \text{ mA}$; $P_D (\text{com.}) = 300 \text{ мВт}$; $h_{21} > 120$	SOT363, SC88	E1•B1•B2•C2•E2•C1
T4	IMT4	ROHM	pnnp x2	$V_{CBO} = 120 \text{ В}$; $I_C = 50 \text{ mA}$; $P_D = 300 \text{ мВт}$; $h_{21} > 180$	SOT23-6	C1•E2•C2•B2•B1•E1
T4	MBD330DW	ON	shd x2	$V_E < 30 \text{ В}$; $V_F (I_F = 10 \text{ mA}) < 0.6 \text{ В}$; $C_T < 1 \text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1•n.c.•K2•A2•n.c.•K1
T76	μPA804TFB	NEC	npn x2	$V_{CBO} = 20 \text{ В}$; $I_C = 60 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 60...120$; $f_T > 3 \text{ ГГц}$	SOT363, SC88	C1•E1•C2•E2•B2•B1
T77	μPA804TGB	NEC	npn x2	$V_{CBO} = 20 \text{ В}$; $I_C = 60 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 100...200$; $f_T > 3 \text{ ГГц}$	SOT363, SC88	C1•E1•C2•E2•B2•B1
T83	μPA806T	NEC	npn x2	$V_{CBO} = 9 \text{ В}$; $I_C = 30 \text{ mA}$; $P_D = 200 \text{ мВт}$; $h_{21} = 75...150$; $f_T = 12 \text{ ГГц}$	SOT363, SC88	C1•E1•C2•E2•B2•B1
T84	μPA807T	NEC	npn x2	$V_{CBO} = 5 \text{ В}$; $I_C = 10 \text{ mA}$; $P_D = 60 \text{ мВт}$; $h_{21} = 70...140$; $f_T > 8.5 \text{ ГГц}$	SOT363, SC88	C1•E1•C2•E2•B2•B1
T86	μPA808T	NEC	npn x2	$V_{CBO} = 5 \text{ В}$; $I_C = 30 \text{ mA}$; $P_D = 180 \text{ мВт}$; $h_{21} = 70...140$; $f_T > 7 \text{ ГГц}$	SOT363, SC88	C1•E1•C2•E2•B2•B1
TCA	ADT7301ART	AD	dts	13-паар.; SPI/OSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7...5.25 \text{ В}$	SOT23-6	GND•DIN•VDD•SCLK•CS•DOUT
TK	HSMS286K	HP	shd x2	$V_F (I_F = 1 \text{ mA}) < 0.35 \text{ В}$; $C_T < 0.30 \text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1•n.c.•A2•K2•n.c.•K1
TL	HSMS286L	HP	shd x3	$V_F (I_F = 1 \text{ mA}) < 0.35 \text{ В}$; $C_T < 0.30 \text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1•A2•A3•K3•K2•K1
TOH	AD7414ARTZ	AD	dts	10-паар.; SMBus/I ² C; $V_{DD} = 2.7...5.5 \text{ В}$	SOT23-6	AS•GND•VDD•SCL•ALERT•SDA
TOJ	AD7414ARTZ	AD	dts	10-паар.; SMBus/I ² C; $V_{DD} = 2.7...5.5 \text{ В}$	SOT23-6	AS•GND•VDD•SCL•ALERT•SDA
TOK	AD7414ARTZ	AD	dts	10-паар.; SMBus/I ² C; $V_{DD} = 2.7...5.5 \text{ В}$	SOT23-6	AS•GND•VDD•SCL•ALERT•SDA
TP	HSMS286P	HP	shd x4	$V_F (I_F = 1 \text{ mA}) < 0.35 \text{ В}$; $C_T < 0.30 \text{ нФ}$	SOT363, SC88	A1•K1, A2•K2•K3•K4, A3•A4

fS6 SON-6 SOT563
M16 USM-6 SOT666



SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4+5+6
TR	HSMS286R	HP	shd x4	$V_F (I_F = 1 \text{ mA}) < 0.35 \text{ В}; C_T < 0.30 \text{ нФ}$	SOT363, SC88	K1 • A1, K2 • A2 • K3 • A3, K4 • A4
VA	RN4601	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VA	RN4901	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VA	RN4901FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 4.7 \text{ кОм}/4.7 \text{ кОм}$	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
YAY1	TLV2630IDBV	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 2.7...5.5 \text{ В}; f_{BW} = 9 \text{ МГц}; V_{OS} < 4.5 \text{ мВ}$	SOT23-6	OUT • GND • IN+ • IN- • SHDN • VDD
VB	RN4602	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 10 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VB	RN4902	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 10 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VB	RN4902FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 10 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}$	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VC	RN4603	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 22 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VC	RN4903	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 22 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VC	RN4903FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 22 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VD	RN4604	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 47 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VD	RN4904	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 47 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VD	RN4904FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 47 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VE	RN4605	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 2.2 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VE	RN4905	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 2.2 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VE	RN4905FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 2.2 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VF	RN4606	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VF	RN4906	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VF	RN4906FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 4.7 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
vH	μPA851TD	NEC	nnp x2	$V_{CE0} = 5 \text{ В}; V_{CE02} = 15 \text{ В}; I_{C1} = 30 \text{ mA}; I_{C2} = 100 \text{ mA};$ $P_D = 210 \text{ мВт}; f_{T1} > 10 \text{ ГГц}; f_{T2} > 4.5 \text{ ГГц}$	M16, 1208	C1 • E1 • C2 • B2 • E2 • B1
VH	RN4607	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 10 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VH	RN4907	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 10 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VH	RN4907FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 10 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VI	RN4608	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 22 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VI	RN4908	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 22 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VI	RN4908FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 22 \text{ кОм}/47 \text{ кОм}$	SOT666	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VJ	RN4609	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 300 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 47 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT23-6	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1
VJ	RN4909	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CE0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ mA}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}$ $R_{\theta J/R_2} = 47 \text{ кОм}/22 \text{ кОм}$	SOT363, SC88	E1 • B1 • C2 • E2 • B2 • C1



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
VJ	RN4909FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_{\theta J/\theta_{\text{PC}}} = 47\text{ К}^{\circ}\text{С}/\text{мм}^2\text{С}^{\circ}\text{К}$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
VK	RN4610	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1 = 4,7\text{ К}^{\circ}\text{С}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
VK	RN4910	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1 = 4,7\text{ К}^{\circ}\text{С}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
VK	RN4910FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1 = 4,7\text{ К}^{\circ}\text{С}$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
vL	μPA854TD	NEC	nnp x2	$V_{CB01} = 9\text{ В}; V_{CB02} = 15\text{ В}; I_{C1} = 30\text{ мА}; I_{C2} = 100\text{ мА}; P_D = 210\text{ мВт}; f_{T1} > 10\text{ ГГц}; f_{T2} > 3\text{ ГГц}$	M16, 1208	C1•E1•C2•B2•E2•B1
VM	RN4611	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1 = 10\text{ К}^{\circ}\text{С}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
VM	RN4911	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1 = 10\text{ К}^{\circ}\text{С}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
VM	RN4911FE	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1 = 10\text{ К}^{\circ}\text{С}$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
vN	μPA855TD	NEC	nnp x2	$V_{CB01} = 5\text{ В}; V_{CB02} = 15\text{ В}; I_{C1} = 30\text{ мА}; I_{C2} = 100\text{ мА}; P_D = 210\text{ мВт}; f_{T1} > 10\text{ ГГц}; f_{T2} > 3\text{ ГГц}$	M16, 1208	C1•E1•C2•B2•E2•B1
VN	RN4612	TOSH	Dnpnp/npn	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц}; R_1 = 22\text{ К}^{\circ}\text{С}$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
vT	μPA859TD	NEC	nnp x2	$V_{CB01} = 5\text{ В}; V_{CB02} = 9\text{ В}; I_{C1} = 30\text{ мА}; I_{C2} = 100\text{ мА}; P_D = 210\text{ мВт}; f_{T1} > 10\text{ ГГц}; f_{T2} > 4\text{ ГГц}$	M16, 1208	C1•E1•C2•B2•E2•B1
vV	μPA860TD	NEC	nnp x2	$V_{CB01} = 9\text{ В}; V_{CB02} = 9\text{ В}; I_{C1} = 30\text{ мА}; I_{C2} = 35\text{ мА}; P_D = 210\text{ мВт}; f_{T1} > 10\text{ ГГц}; f_{T2} > 17\text{ ГГц}$	M16, 1208	C1•E1•C2•B2•E2•B1
vX	μPA861TD	NEC	nnp x2	$V_{CB01} = 5\text{ В}; V_{CB02} = 9\text{ В}; I_{C1} = 30\text{ мА}; I_{C2} = 35\text{ мА}; P_D = 195\text{ мВт}; f_{T1} > 10\text{ ГГц}; f_{T2} > 17\text{ ГГц}$	M16, 1208	C1•E1•C2•B2•E2•B1
vY	μPA862TD	NEC	nnp x2	$V_{CB01} = 9\text{ В}; V_{CB02} = 9\text{ В}; I_{C1} = 30\text{ мА}; I_{C2} = 100\text{ мА}; P_D = 210\text{ мВт}; f_{T1} > 10\text{ ГГц}; f_{T2} > 3\text{ ГГц}$	M16, 1208	C1•E1•C2•B2•E2•B1
vY	μPA862TS	NEC	nnp x2	$V_{CB01} = 9\text{ В}; V_{CB02} = 9\text{ В}; I_{C1} = 30\text{ мА}; I_{C2} = 100\text{ мА}; P_D = 130\text{ мВт}; f_{T1} > 10\text{ ГГц}; f_{T2} > 3\text{ ГГц}$	SOT666	C1•E1•C2•B2•E2•B1
W10	FMW10	ROHM	nnp x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 27$	SOT23-6	C1•C2•B2•E1, E2•B1•n.c.
W10	UMW10N	ROHM	nnp x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D(\text{com.}) = 300\text{ мВт}; h_{21} > 27; \dots; 270; f_T > 1500\text{ МГц}$	SOT363, SC88	B1•E1, E2•B2•C2•C1•n.c.
W1s	BCR10PN	INF	Dnpnp(2) +nnp(1)	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 30; f_T = 130\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
W5	SEMB10	INF	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 70\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T = 100\text{ МГц}$	SOT666	E1•B1•C1•E2•B2•C2
W8	FMW8	ROHM	nnp x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 27$	SOT457, SC74	C1•n.c. • C2•B2•E1, E2•B1
WC	SEMH11	INF	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 30; f_T = 130\text{ МГц}$	SOT666	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WCs	BCR133S	INF	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 30; f_T = 130\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
WCs	BCR133U	INF	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 30; f_T = 130\text{ МГц}$	SOT457, SC74	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WD	SEMH1	INF	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 130\text{ МГц}$	SOT666	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WDS	BCR141S	INF	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 130\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WDS	BCR141U	INF	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T > 130\text{ МГц}$	SOT457, SC74	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WE	SEMH1	INF	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 70\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT666	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WEs	BCR148S	INF	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 70\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WEs	BCR148U	INF	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 70\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT457, SC74	E1•B1•C1•E2•B2•C2

fS6 SON-6
M16 USM-6SOT563
SOT666SOT363 SOT457 SOT23-6
TSOT363 MW-6 TSOT23-6

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
WFs	BCR08PN	INF	Dnpn(2) +npn(1)	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 70;$ $f_T = 170\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
WH	SEM110	INF	Dnpn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 70;$ $f_T > 170\text{ МГц}$	SOT666	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WHs	BCR108S	INF	Dnpn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; h_{21} > 70;$ $f_T > 170\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WJ	SEM19	INF	Dnpn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 70;$ $f_T > 150\text{ МГц}$	SOT666	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WJs	BCR135S	INF	Dnpn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 70;$ $f_T > 150\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
Wks	BCR119S	INF	Dnpn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт};$ $h_{21} = 120...630; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WMs	BCR183S	INF	Dnpn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 30;$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
WMs	BCR183U	INF	Dnpn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 30;$	SOT457, SC74	E1•B1•C2•E2•B2•C1
WNs	BCR185S	INF	Dnpn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 70;$ $f_T > 200\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WNs	BCR185U	INF	Dnpn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 70;$ $f_T > 200\text{ МГц}$	SOT457, SC74	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WOs	BCR191S	INF	Dnpn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 50;$ $f_T > 200\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WPs	BCR192U	INF	Dnpn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 70;$ $f_T > 200\text{ МГц}$	SOT457, SC74	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WPs	BCR22PN	INF	Dnpn(2) +npn(1)	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 50;$ $f_T = 130\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
WRs	BCR198S	INF	D2 npn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 70\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 70;$ $f_T > 190\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WSs	BCR169S	INF	Dnpn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт};$ $h_{21} = 120...630; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WTs	BCR48PN	INF	Dnpn(1) +npn(2)	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_{CNPN} = 70\text{ мА}; I_{CPNP} = 100\text{ мА};$ $P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 70; f_T > 100\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WU	MRF2947AT1	MOT	npn x2	$V_{CB0} = 20\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 188\text{ мВт}; h_{21} = 75...150;$ $f_T = 9\text{ ГГц}$	SOT363, SC88	B1•E2•C2•B2•E1•C1
WVs	BCR129S	INF	Dnpn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт};$ $h_{21} = 120...630; f_T > 150\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
WVs	BCR35PN	INF	Dnpn(1) +npn(2)	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 250\text{ мВт}; h_{21} > 70;$ $f_T > 150\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•C1•E2•B2•C2
X1	EMX1	ROHM	npn x2	$V_{CB0} = 60\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT563, EMT6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
X1	IMX1	ROHM	npn x2	$V_{CB0} = 60\text{ В}; I_C = 150\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT23-6	C1•B2•E2•C2•B1•E1
X1	UMX1N	ROHM	npn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D(\text{com.}) = 300\text{ мВт};$ $h_{21} > 120$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
X11	UMX11N	ROHM	npn x2	$V_{CB0} = 25\text{ В}; I_C = 20\text{ мА}; h_{21} = 39...180; f_T > 700\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•B2•C2•E2•C1
X17	IMX17	ROHM	npn x2	$V_{CB0} = 60\text{ В}; I_C = 150\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT23-6	C1•B2•E2•C2•B1•E1
X2	IMX2	ROHM	npn x2	$V_{CB0} = 60\text{ В}; I_C = 150\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT23-6	C1•B1•C2•B2•E2•E1
X2	UMX2N	ROHM	npn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D(\text{com.}) = 300\text{ мВт};$ $h_{21} > 120$	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
X3	IMX3	ROHM	npn x2	$V_{CB0} = 60\text{ В}; I_C = 150\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT23-6	C1•E2•C2•B2•B1•E1
X3	UMX3N	ROHM	npn x2	$V_{CB0} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D(\text{com.}) = 300\text{ мВт};$ $h_{21} > 120$	SOT363, SC88	E1•B1•B2•C2•E2•C1
X4	EMX4	ROHM	npn x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 27$	SOT563, EMT6	E1•B1•B2•C2•E2•C1
X4	IMX4	ROHM	npn x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 27$	SOT23-6	C1•E2•C2•B2•B1•E1
X4	UMX4N	ROHM	npn x2	$V_{CB0} = 30\text{ В}; I_C = 50\text{ мА}; P_D(\text{com.}) = 300\text{ мВт};$ $h_{21} = 56...180; f_T > 1500\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1•B1•B2•C2•E2•C1



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
X5	IMX5	ROHM	nрn x2	$V_{CEB} = 20 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 27$	SOT23-6	C1•E2•C2•B2•B1•E1
X5	UMX5N	ROHM	nрn x2	$V_{CEB} = 30 В; I_C = 50 мА; P_D (com.) = 300 мВт; h_{21} = 56...180; f_T > 1500 МГц$	SOT363, SC88	E1•B1•B2•C2•E2•C1
X6	UMX6N	ROHM	nрn x2	$V_{CEB} = 40 В; I_C = 50 мА; P_D (com.) = 300 мВт; h_{21} > 56; f_T > 300 МГц$	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
X8	IMX8	ROHM	nрn x2	$V_{CEB} = 120 В; I_C = 50 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 180$	SOT23-6	C1•E2•C2•B2•B1•E1
X9	IMX9	ROHM	nрn x2	$V_{CEB} = 25 В; I_C = 500 мА; P_D = 300 мВт; h_{21} > 560$	SOT23-6	C1•B2•E2•C2•B1•E1
XA	RN1601	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XA	RN1901	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XA	RN1901FE	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/4.7 кОм$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XB	RN1602	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XB	RN1902	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XB	RN1902FE	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/10 кОм$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
xC	μPA863TD	NEC	nрn x2	$V_{CEB1} = 5 В; V_{CEB2} = 9 В; I_{C1} = 30 мА; I_{C2} = 100 мА; P_D = 130 мВт; f_{T1} > 10 ГГц; f_{T2} > 3 ГГц$	M16, 1208	C1•E1•C2•B2•E2•B1
xC	μPA863TS	NEC	nрn x2	$V_{CEB1} = 5 В; V_{CEB2} = 9 В; I_{C1} = 30 мА; I_{C2} = 100 мА; P_D = 130 мВт; f_{T1} > 10 ГГц; f_{T2} > 3 ГГц$	SOT666	C1•E1•C2•B2•E2•B1
XC	RN1603	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XC	RN1903	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XC	RN1903FE	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/22 кОм$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XD	RN1604	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XD	RN1904	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XD	RN1904FE	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 47 кОм/47 кОм$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XE	RN1605	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XE	RN1905	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XE	RN1905FE	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 2.2 кОм/47 кОм$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XF	RN1606	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XF	RN1906	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XF	RN1906FE	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 4.7 кОм/47 кОм$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XH	RN1607	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XH	RN1907	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XH	RN1907FE	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 100 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 10 кОм/47 кОм$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XI	RN1608	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 300 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
XI	RN1908	TOSH	Dnрn x2	$V_{CEB} = 50 В; I_C = 100 мА; P_D = 200 мВт; f_T = 250 МГц; R_1/R_2 = 22 кОм/47 кОм$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
XXK	RN1970	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} = 4,7 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXK	RN1970FE	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} = 4,7 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXM	RN1971	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} = 10 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXM	RN1971FE	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 250 \text{ МГц}; R_{\theta} = 10 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
XXP	RN1973	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; R_{\theta} = 47 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
Y0s	CGY121B	SIEM	amp	GaAs; $V_{CC} = 2,7 \dots 6 \text{ В}; f_{BD} = 0,8 \dots 2,5 \text{ ГГц}$	MW-6	V2/RF-OUT•RF-GND•VD1•RF-IN•RF-GND•VCONTR
Y2	CLY2	SIEM	nFET	GaAs; $V_{GS} = 9 \text{ В}; I_B = 600 \text{ мА}; P_D = 900 \text{ мВт}; I_{loss} = 650 \text{ мА}$	MW-6	G•S•D•D•S•G
Y5s	CGY59	SIEM	amp	GaAs; $f_{BD} = 0,9/1,8 \text{ ГГц}$	SOT363, SC88	DC-GND•RF-GND•IN•OUT•RF-GND•VD
Y6s	CGY62	SIEM	amp	GaAs; $V_{CC} = 2,7 \dots 5,8 \text{ В}; f_{BD} = 0,2 \dots 2,5 \text{ ГГц}$	MW-6	OUT•GND•INTERS•IN•GND•GND
Y7	CGY60	SIEM	amp	GaAs; $f_{BD} = 1,8 \text{ ГГц}$	MW-6	DC-GND•RF-GND•IN•OUT•RF-GND•VD
Y8	CGY120	SIEM	amp	GaAs; $V_{CC} = 2,7 \dots 6 \text{ В}; f_{BD} = 0,8 \dots 2,5 \text{ ГГц}$	MW-6	IN•GND•VCONTR•OUT•GND•VD1
Y9s	CGY121A	SIEM	amp	GaAs; $V_{CC} = 2,7 \dots 6 \text{ В}; f_{BD} = 0,8 \dots 2,5 \text{ ГГц}$	MW-6	V2/RF-OUT•RF-GND•VD1•RF-IN•RF-GND•VCONTR
YA	RN2601	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 4,7 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/4,7 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YA	RN2901	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 4,7 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/4,7 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YA	RN2901FE	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 4,7 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/4,7 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YB	RN2602	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 10 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/10 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YB	RN2902	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 10 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/10 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YB	RN2902FE	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 10 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/10 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YC	RN2603	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 22 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/22 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YC	RN2903	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 22 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/22 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YC	RN2903FE	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 22 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/22 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YD	RN2604	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 47 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/47 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YD	RN2904	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 47 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/47 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YD	RN2904FE	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 47 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/47 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YE	RN2605	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 2,2 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/47 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YE	RN2905	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 2,2 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/47 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YE	RN2905FE	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 100 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 2,2 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/47 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT666	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YF	RN2606	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 4,7 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/47 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT23-6	E1•B1•C2•E2•B2•C1
YF	RN2906	TOSH	Dnpnp x2	$V_{CB0} = 50 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 200 \text{ мВт}; f_T = 200 \text{ МГц}; R_{\theta}/R_{\theta 2} = 4,7 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2/47 \text{ К}^{\circ}\text{С/м}^2$	SOT363, SC88	E1•B1•C2•E2•B2•C1



SOT23-6 SOT457 SOT363
TSOT23-6 MW-6 TSOT363



SOT563 SON-6 fS6
SOT666 USM-6 M16

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6
YUH	RN2967FE	TOSH	Dnpn x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц};$ $R_{\theta J/R_{\theta 2}} = 10\text{ К}^{\circ}\text{Ом}/47\text{ К}^{\circ}\text{Ом}$	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYI	RN2968	TOSH	Dnpn x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц};$ $R_{\theta J/R_{\theta 2}} = 22\text{ К}^{\circ}\text{Ом}/47\text{ К}^{\circ}\text{Ом}$	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYI	RN2968FE	TOSH	Dnpn x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц};$ $R_{\theta J/R_{\theta 2}} = 22\text{ К}^{\circ}\text{Ом}/47\text{ К}^{\circ}\text{Ом}$	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYJ	RN2969	TOSH	Dnpn x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц};$ $R_{\theta J/R_{\theta 2}} = 47\text{ К}^{\circ}\text{Ом}/22\text{ К}^{\circ}\text{Ом}$	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYJ	RN2969FE	TOSH	Dnpn x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц};$ $R_{\theta J/R_{\theta 2}} = 47\text{ К}^{\circ}\text{Ом}/22\text{ К}^{\circ}\text{Ом}$	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYK	RN2970	TOSH	Dnpn x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц};$ $R_{\theta 1} = 4,7\text{ К}^{\circ}\text{Ом}$	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYK	RN2970FE	TOSH	Dnpn x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц};$ $R_{\theta 1} = 4,7\text{ К}^{\circ}\text{Ом}$	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYM	RN2971	TOSH	Dnpn x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц};$ $R_{\theta 1} = 10\text{ К}^{\circ}\text{Ом}$	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YYM	RN2971FE	TOSH	Dnpn x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 100\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц};$ $R_{\theta 1} = 10\text{ К}^{\circ}\text{Ом}$	SOT666	E1•E2•B2•C2•B1•C1
YY5	RN2975	TOSH	Dnpn x2	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D = 200\text{ мВт}; f_T = 200\text{ МГц};$ $R_{\theta J/R_{\theta 2}} = 2,2\text{ К}^{\circ}\text{Ом}/10\text{ К}^{\circ}\text{Ом}$	SOT363, SC88	E1•E2•B2•C2•B1•C1
Z1	EMZ1	ROHM	npn/npn	$V_{CEB} = 60\text{ В}; I_C = 150\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT563, EMT6	E1•B1•C2 • E2•B2•C1
Z1	IMZ1A	ROHM	npn/npn	$V_{CEB} = 60\text{ В}; I_C = 150\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT23-6	C1•B2•E2•C2 • B1•E1
Z1	UMZ1N	ROHM	npn(2)+npn (1)	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D(\text{com.}) = 300\text{ мВт};$ $h_{21} = 120...560; f_T > 400\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1 • B1•C2•E2•B2•C1
Z2	EMZ2	ROHM	npn/npn	$V_{CEB} = 60\text{ В}; I_C = 150\text{ мА}; P_D = 150\text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT563, EMT6	E1•B1•B2•C2•E2•C1
Z2	IMZ2A	ROHM	npn/npn	$V_{CEB} = 60\text{ В}; I_C = 150\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT23-6	C1•E2•C2•B2•B1•E1
Z2	UMZ2N	ROHM	npn(1)+npn (2)	$V_{CEB} = 50\text{ В}; I_C = 100\text{ мА}; P_D(\text{com.}) = 300\text{ мВт};$ $h_{21} = 120...560; f_T > 180\text{ МГц}$	SOT363, SC88	E1 • B1•B2•C2•E2•C1
Z4	IMZ4	ROHM	npn/npn	$V_{CEB} = 40\text{ В}; I_C = 500\text{ мА}; P_D = 300\text{ мВт}; h_{21} > 120$	SOT23-6	C1•B2•E2•C2 • B1•E1
ZS20	ZHCS2000	ZETEX	shd	$V_B < 40\text{ В}; I_C < 2\text{ А}; V_{\theta} (I_{\theta} = 3\text{ А}) < 0,615\text{ В};$ $I_{\theta} < 300\text{ мА}; C_{\theta} = 50\text{ нФ}$	SOT23-6	K•K•A•A•K•K

MSOP-10



US-8

SOT23-8
TSOT23-8MSOP-8
SOP-8

MSOP/SOP-8/10

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
#DDB	AD5304BRMZ	AD	DAC	4x8-паэр.; SPI/Microwire; $V_{DD}=2.5...5.5\text{ В}$	MSOP-10	VDD•VOUTA•VOUTB•VOUTC•REFIN•VOUTD•GND•DIN•SCLK•SYNC
#DCA	AD5314ARMZ	AD	DAC	4x10-паэр.; SPI/Microwire; $V_{DD}=2.5...5.5\text{ В}$	MSOP-10	VDD•VOUTA•VOUTB•VOUTC•REFIN•VOUTD•GND•DIN•SCLK•SYNC
#DCB	AD5314BRMZ	AD	DAC	4x10-паэр.; SPI/Microwire; $V_{DD}=2.5...5.5\text{ В}$	MSOP-10	VDD•VOUTA•VOUTB•VOUTC•REFIN•VOUTD•GND•DIN•SCLK•SYNC
#DDB	AD5324BRMZ	AD	DAC	4x12-паэр.; SPI/Microwire; $V_{DD}=2.5...5.5\text{ В}$	MSOP-10	VDD•VOUTA•VOUTB•VOUTC•REFIN•VOUTD•GND•DIN•SCLK•SYNC
#HCA	AD8062ARMZ	AD	dOA	$f_{EO}=320\text{ МГц}$; $P_D=75\text{ мВт}$; $V_{DD}=2.7...8\text{ В}$	MSOP-8	VOUT1•-IN1•+IN1•-VS•+IN2•-IN2•VOUT2•+VS
0412	LT1004CS8-1.2	LT	vref	$V_{OUT}=1.2\text{ В}$; $ACC=\pm 4\text{ мВ}$	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • n.c. • VOUT • n.c. • VOUT
0412I	LT1004IS8-1.2	LT	vref	$V_{OUT}=1.2\text{ В}$; $ACC=\pm 4\text{ мВ}$	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • n.c. • VOUT • n.c. • VOUT
0425	LT1004CS8-2.5	LT	vref	$V_{OUT}=2.5\text{ В}$; $ACC=\pm 20\text{ мВ}$	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • n.c. • VOUT • n.c. • VOUT
0425I	LT1004IS8-2.5	LT	vref	$V_{OUT}=2.5\text{ В}$; $ACC=\pm 20\text{ мВ}$	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • n.c. • VOUT • n.c. • VOUT
1001	LT1001CS8	LT	OA	$V_{OSI}<60\text{ мкВ}$; $V_{DD}=\pm 15\text{ В}$; $P_D<80\text{ мВт}$	SOP-8	VOSTRIM•-IN•+IN•V•-n.c. • OUT•V•+VOSTRIM
1006	LT1006S8	LT	OA	$V_{OSI}<50\text{ мкВ}$; $V_{DD}>2.7\text{ В}$; $P_D<80\text{ мВт}$	SOP-8	VOSTRIM•-IN•+IN•V•-VOSTRIM•OUT•V•+ISY SET
1007	LT1007CS8	LT	OA	$V_{OSI}<60\text{ мкВ}$; $V_{DD}>2.7\text{ В}$; $P_D<160\text{ мВт}$	SOP-8	VOSTRIM•-IN•+IN•V•-n.c. • OUT•V•+VOSTRIM
1007I	LT1007IS8	LT	OA	$V_{OSI}<60\text{ мкВ}$; $V_{DD}>2.7\text{ В}$; $P_D<160\text{ мВт}$	SOP-8	VOSTRIM•-IN•+IN•V•-n.c. • OUT•V•+VOSTRIM
1008	LT1008S8	LT	OA	$V_{OSI}<180\text{ мкВ}$; $V_{DD}>2.7\text{ В}$	SOP-8	COMP1•-IN•+IN•V•-n.c. • OUT•V•+COMP2
1009	LT1009S8	LT	vref	$V_{OUT}=2.5\text{ В}$; $ACC<0.2\%$; $T_{AMB}=0...70\text{ °C}$	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • (-)•ADJ•(+)•n.c. • (+)
1009I	LT1009IS8	LT	vref	$V_{OUT}=2.5\text{ В}$; $ACC<0.2\%$; $T_{AMB}=-40...85\text{ °C}$	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • (-)•ADJ•(+)•n.c. • (+)
1011	LT1011CS8	LT	cmp	$V_{OSI}<0.5\text{ мВ}$; $V_{DD}=\pm 15\text{ В}$; $T_{AMB}=0...70\text{ °C}$	SOP-8	GND•INPUT•INPUT•V•-BAL•BAL/STR•OUTPUT•V+
1011AI	LT1011AIS8	LT	cmp	$V_{OSI}<0.5\text{ мВ}$; $V_{DD}=\pm 15\text{ В}$; $T_{AMB}=-55...125\text{ °C}$	SOP-8	GND•INPUT•INPUT•V•-BAL•BAL/STR•OUTPUT•V+
1011I	LT1011IS8	LT	cmp	$V_{OSI}<0.5\text{ мВ}$; $V_{DD}=\pm 15\text{ В}$; $T_{AMB}=-40...85\text{ °C}$	SOP-8	GND•INPUT•INPUT•V•-BAL•BAL/STR•OUTPUT•V+
1012	LT1012S8	LT	OA	$V_{OSI}<25\text{ мкВ}$; $V_{DD}=\pm 15\text{ В}$; $I_D<600\text{ мкА}$; $T_{AMB}=0...70\text{ °C}$	SOP-8	VOSTRIM•-IN•+IN•V•-OVER COMP•OUT•V•+VOSTRIM
1012A	LT1012ACS8	LT	OA	$V_{OSI}<25\text{ мкВ}$; $V_{DD}=\pm 15\text{ В}$; $I_D<600\text{ мкА}$; $T_{AMB}=0...70\text{ °C}$	SOP-8	VOSTRIM•-IN•+IN•V•-OVER COMP•OUT•V•+VOSTRIM
1012AI	LT1012AIS8	LT	OA	$V_{OSI}<25\text{ мкВ}$; $V_{DD}=\pm 15\text{ В}$; $I_D<600\text{ мкА}$; $T_{AMB}=-40...85\text{ °C}$	SOP-8	VOSTRIM•-IN•+IN•V•-OVER COMP•OUT•V•+VOSTRIM
1012I	LT1012IS8	LT	OA	$V_{OSI}<25\text{ мкВ}$; $V_{DD}=\pm 15\text{ В}$; $I_D<600\text{ мкА}$; $T_{AMB}=-40...85\text{ °C}$	SOP-8	VOSTRIM•-IN•+IN•V•-OVER COMP•OUT•V•+VOSTRIM
1013	LT1013DS8	LT	dOA	$V_{OSI}<150\text{ мкВ}$; $V_{DD}=\pm 15\text{ В}$; $I_D<550\text{ мкА}$; $T_{AMB}=0...70\text{ °C}$	SOP-8	+INA•V•+INB•-INB•OUTB•V•+OUTA•-INA
1013I	LT1013IS8	LT	dOA	$V_{OSI}<150\text{ мкВ}$; $V_{DD}=\pm 15\text{ В}$; $I_D<550\text{ мкА}$; $T_{AMB}=-40...85\text{ °C}$	SOP-8	+INA•V•+INB•-INB•OUTB•V•+OUTA•-INA
1016	LT1016CS8	LT	cmp	$V_{OSI}<0.5\text{ мВ}$; $V_{DD}=5/\pm 5\text{ В}$; $I_{PD}=10\text{ нС}$; $T_{AMB}=0...70\text{ °C}$	SOP-8	V•+•IN•-IN•V•-LAT ENBL•GND•Q OUT•Q OUT
1016I	LT1016IS8	LT	cmp	$V_{OSI}<0.5\text{ мВ}$; $V_{DD}=5/\pm 5\text{ В}$; $I_{PD}=10\text{ нС}$; $T_{AMB}=-40...85\text{ °C}$	SOP-8	V•+•IN•-IN•V•-LAT ENBL•GND•Q OUT•Q OUT
1017	LT1017CS8	LT	cmp	$V_{OSI}<1\text{ мВ}$; $V_{DD}=1.1...40\text{ В}$; $T_{AMB}=0...70\text{ °C}$	SOP-8	+IN A•V•-+IN B•-IN B•OUT B•V•+OUT A•-IN A



MSOP-8 SOT23-8
SOP-8 TSOT23-8 US-8



MSOP-10

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
10171	LT1017IS8	LT	cmp x2	$V_{OSI} < 1 \text{ мВ}; V_{DD} = 1.1...40 \text{ В}; T_{AMB} = -40...85^\circ \text{C}$	SOP-8	+IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+ • OUT A • -IN A
1018	LT1018CS8	LT	cmp x2	$V_{OSI} < 1 \text{ мВ}; V_{DD} = 1.1...40 \text{ В}; T_{AMB} = 0...70^\circ \text{C}$	SOP-8	+IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+ • OUT A • -IN A
1026	LT1026CS8	LT	vcon	$V_{OUT} = \pm 18 \text{ В}; I_{OUT} > 10 \text{ мА}; T_{AMB} = 0...70^\circ \text{C}$	SOP-8	C1 • C2 • C2 • -VOUT • GND • VIN • C1+ • +VOUT
1026I	LT1026IS8	LT	vcon	$V_{OUT} = \pm 18 \text{ В}; I_{OUT} > 10 \text{ мА}; T_{AMB} = -40...85^\circ \text{C}$	SOP-8	C1 • C2 • C2 • -VOUT • GND • VIN • C1+ • +VOUT
1027C5	LT1027CCS8-5	LT	vref	$V_{OUT} = 5 \text{ В}; T_{AMB} = 0...70^\circ \text{C}; T_{COUT} < 3 \text{ ppm}/^\circ \text{C}$	SOP-8	NR • GND • VTRIM • VOUT • n.c. • n.c. • n.c. • VIN
1027D5	LT1027DCS8-5	LT	vref	$V_{OUT} = 5 \text{ В}; T_{AMB} = 0...70^\circ \text{C}; T_{COUT} < 5 \text{ ppm}/^\circ \text{C}$	SOP-8	NR • GND • VTRIM • VOUT • n.c. • n.c. • n.c. • VIN
1027E5	LT1027ECS8-5	LT	vref	$V_{OUT} = 5 \text{ В}; T_{AMB} = 0...70^\circ \text{C}; T_{COUT} < 7.5 \text{ ppm}/^\circ \text{C}$	SOP-8	NR • GND • VTRIM • VOUT • n.c. • n.c. • n.c. • VIN
1028	LT1028CS8	LT	OA	$V_{OSI} < 40 \text{ мкВ}; V_{DD} = \pm 15 \text{ В}; I_0 < 10.5 \text{ мА}; T_{AMB} = -40...85^\circ \text{C}$	SOP-8	VOSTRIM • -IN • +IN • V- • OVER COMP • OUT • V+ • VOSTRIM
103412	LT1034IS8-1.2	LT	vref x2	$V_{OUT1} = 1.2 \text{ В}; V_{OUT2} = 7 \text{ В}; T_{AMB} = -40...85^\circ \text{C}$	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • 7V • 2.5V • n.c. • 2.5V
1037	LT1037CS8	LT	OA	$V_{OSI} < 60 \text{ мкВ}; V_{DD} > 2.7 \text{ В}; P_D < 160 \text{ мВт}$	SOP-8	VOSTRIM • -IN • +IN • V- • n.c. • OUT • V+ • VOSTRIM
1054	LT1054CS8	LT	vcon + fbg	$V_{CC} = 3.5...15 \text{ В}; I_{OUT} = 100 \text{ мА}; T_{AMB} = 0...100^\circ \text{C}$	SOP-8	FB/SHDN • CAP+ • GND • CAP- • VOUT • VREF • OSC • V+
1054A	LT1054ACS8	LT	vcon + fbg	$V_{CC} = 3.5...15 \text{ В}; I_{OUT} = 100 \text{ мА}; T_{AMB} = 0...100^\circ \text{C}$	SOP-8	FB/SHDN • CAP+ • GND • CAP- • VOUT • VREF • OSC • V+
1054I	LT1054IS8	LT	vcon + fbg	$V_{CC} = 3.5...15 \text{ В}; I_{OUT} = 100 \text{ мА}; T_{AMB} = -40...100^\circ \text{C}$	SOP-8	FB/SHDN • CAP+ • GND • CAP- • VOUT • VREF • OSC • V+
1054L	LT1054LCS8	LT	vcon + fbg	$V_{CC} = 3.5...7 \text{ В}; I_{OUT} = 100 \text{ мА}; T_{AMB} = 0...100^\circ \text{C}$	SOP-8	FB/SHDN • CAP+ • GND • CAP- • VOUT • VREF • OSC • V+
1055	LT1055S8	LT	OA	$V_{OSI} < 150 \text{ мкВ}; V_{DD} = \pm 15 \text{ В}; I_0 < 7 \text{ мА}; T_{AMB} = 0...70^\circ \text{C}$	SOP-8	BAL • -IN • +IN • V- • BAL • OUT • V+ • n.c.
1056	LT1056S8	LT	OA	$V_{OSI} < 150 \text{ мкВ}; V_{DD} = \pm 15 \text{ В}; I_0 < 7 \text{ мА}; T_{AMB} = 0...70^\circ \text{C}$	SOP-8	BAL • -IN • +IN • V- • BAL • OUT • V+ • n.c.
1057	LT1057S8	LT	dOA	$V_{OSI} < 450 \text{ мкВ}; V_{DD} = \pm 15 \text{ В}; I_0 < 2.8 \text{ мА}; T_{AMB} = 0...70^\circ \text{C}$	SOP-8	+IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+ • OUT A • -IN A
1057I	LT1057IS8	LT	dOA	$V_{OSI} < 450 \text{ мкВ}; V_{DD} = \pm 15 \text{ В}; I_0 < 2.8 \text{ мА}; T_{AMB} = -40...85^\circ \text{C}$	SOP-8	+IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+ • OUT A • -IN A
1072	LT1072CS8	LT	reg	$V_{IN} = 3...60 \text{ В}; f_{SW} = 40 \text{ кГц}$	SOP-8	GND • VC • FB • n.c. • VIN • E1 • VSW • E2
1073	LT1073CS8	LT	dcdc	$V_{IN} = 1...30 \text{ В}; I_0 < 130 \text{ мкА}$	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE
107312	LT1073CS8-12	LT	dcdc	$V_{IN} = 1...30 \text{ В}; V_{OUT} = 12 \text{ В}; I_0 < 130 \text{ мкА}$	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE
10735	LT1073CS8-5	LT	dcdc	$V_{IN} = 1...30 \text{ В}; V_{OUT} = 5 \text{ В}; I_0 < 130 \text{ мкА}$	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE
1077	LT1077S8	LT	OA	$V_{OSI} < 40 \text{ мкВ}; V_{DD} = 5 \text{ В}; I_0 < 68 \text{ мкА}; T_{AMB} = 0...70^\circ \text{C}$	SOP-8	VOS TRIM • -IN • +IN • V- • n.c. • OUT • V+ • VOS TRIM
1077I	LT1077IS8	LT	OA	$V_{OSI} < 40 \text{ мкВ}; V_{DD} = 5 \text{ В}; I_0 < 68 \text{ мкА}; T_{AMB} = -40...85^\circ \text{C}$	SOP-8	VOS TRIM • -IN • +IN • V- • n.c. • OUT • V+ • VOS TRIM
1078	LT1078S8	LT	dOA	$V_{OSI} < 70 \text{ мкВ}; V_{DD} = 5 \text{ В}; I_0 < 68 \text{ мкА}; T_{AMB} = 0...70^\circ \text{C}$	SOP-8	+IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+ • OUT A • -IN A
1078I	LT1078IS8	LT	dOA	$V_{OSI} < 70 \text{ мкВ}; V_{DD} = 5 \text{ В}; I_0 < 68 \text{ мкА}; T_{AMB} = -40...85^\circ \text{C}$	SOP-8	+IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+ • OUT A • -IN A
10905	LT1109CS8-5	LT	dcdc	$V_{IN} = 3...20 \text{ В}; V_{OUT} = 5 \text{ В}; I_0 < 320 \text{ мкА}; T_{AMB} = 0...70^\circ \text{C}$	SOP-8	VIN • n.c. • SW • GND • n.c. • n.c. • SHUTDOWN • SENSE
10912	LT1109CS8-12	LT	dcdc	$V_{IN} = 3...20 \text{ В}; V_{OUT} = 12 \text{ В}; I_0 < 320 \text{ мкА}; T_{AMB} = 0...70^\circ \text{C}$	SOP-8	VIN • n.c. • SW • GND • n.c. • n.c. • SHUTDOWN • SENSE
1097	LT1097S8	LT	OA	$V_{OSI} < 50 \text{ мкВ}; V_{DD} = \pm 15 \text{ В}; I_0 < 0.7 \text{ мА}; T_{AMB} = -40...85^\circ \text{C}$	SOP-8	VOS TRIM • -IN • +IN • V- • OVER COMP • OUT • V+ • VOS TRIM
11012	LT1110CS8-12	LT	dcdc	$V_{IN} = 1...30 \text{ В}; V_{OUT} = 12 \text{ В}; T_{AMB} = 0...70^\circ \text{C}$	SOP-8	ILIM • VIN • SW1 • SW2 • GND • A0 • SET • FB/SENSE

MSOP-10



US-8

SOT23-8
TSOT23-8MSOP-8
SOP-8

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
1107	LT1107CS8	LT	ddcdc	$V_{IN}=2...30\text{ В}; I_S < 450\text{ мкА}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	ILIM•VIN•SW1•SW2•GND•AO•SET•FB/SENSE
110712	LT1107CS8-12	LT	ddcdc	$V_{IN}=2...30\text{ В}; V_{OUT}=12\text{ В}; I_S < 450\text{ мкА}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	ILIM•VIN•SW1•SW2•GND•AO•SET•FB/SENSE
11075	LT1107CS8-5	LT	ddcdc	$V_{IN}=2...30\text{ В}; V_{OUT}=5\text{ В}; I_S < 450\text{ мкА}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	ILIM•VIN•SW1•SW2•GND•AO•SET•FB/SENSE
11071	LT1107S8	LT	ddcdc	$V_{IN}=2...30\text{ В}; I_S < 450\text{ мкА}; T_{AMB}=-40...85\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	ILIM•VIN•SW1•SW2•GND•AO•SET•FB/SENSE
1108	LT1108CS8	LT	ddcdc	$V_{IN}=2...30\text{ В}; I_S < 110\text{ мкА}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	ILIM•VIN•SW1•SW2•GND•AO•SET•FB/SENSE
11081	LT1108CS8-12	LT	ddcdc	$V_{IN}=2...30\text{ В}; V_{OUT}=12\text{ В}; I_S < 110\text{ мкА}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	ILIM•VIN•SW1•SW2•GND•AO•SET•FB/SENSE
11085	LT1108CS8-5	LT	ddcdc	$V_{IN}=2...30\text{ В}; V_{OUT}=5\text{ В}; I_S < 110\text{ мкА}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	ILIM•VIN•SW1•SW2•GND•AO•SET•FB/SENSE
1109	LT1109CS8	LT	ddcdc	$V_{IN}=3...20\text{ В}; I_S < 320\text{ мкА}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	VIN•n.c. • SW•GND•n.c. • n.c. • SHUTDOWN•SENSE
1109A	LT1109ACS8	LT	ddcdc	$V_{IN}=3...20\text{ В}; I_S < 320\text{ мкА}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	VIN•n.c. • SW•GND•n.c. • n.c. • SHUTDOWN•SENSE
1109A1	LT1109ACS8-12	LT	ddcdc	$V_{IN}=3...20\text{ В}; V_{OUT}=12\text{ В}; I_S < 320\text{ мкА}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	VIN•n.c. • SW•GND•n.c. • n.c. • SHUTDOWN•SENSE
1109A5	LT1109ACS8-5	LT	ddcdc	$V_{IN}=3...20\text{ В}; V_{OUT}=5\text{ В}; I_S < 320\text{ мкА}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	VIN•n.c. • SW•GND•n.c. • n.c. • SHUTDOWN•SENSE
1110	LT1110CS8	LT	ddcdc	$V_{IN}=1...30\text{ В}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	ILIM•VIN•SW1•SW2•GND•AO•SET•FB/SENSE
11105	LT1110CS8-5	LT	ddcdc	$V_{IN}=1...30\text{ В}; V_{OUT}=5\text{ В}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	ILIM•VIN•SW1•SW2•GND•AO•SET•FB/SENSE
1111	LT1111CS8	LT	ddcdc	$V_{IN}=2...30\text{ В}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	ILIM•VIN•SW1•SW2•GND•AO•SET•FB/SENSE
11111	LT1111CS8-12	LT	ddcdc	$V_{IN}=2...30\text{ В}; V_{OUT}=12\text{ В}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	ILIM•VIN•SW1•SW2•GND•AO•SET•FB/SENSE
11115	LT1111CS8-5	LT	ddcdc	$V_{IN}=2...30\text{ В}; V_{OUT}=5\text{ В}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	ILIM•VIN•SW1•SW2•GND•AO•SET•FB/SENSE
11111	LT1111IS8	LT	ddcdc	$V_{IN}=2...30\text{ В}; T_{AMB}=-40...85\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	ILIM•VIN•SW1•SW2•GND•AO•SET•FB/SENSE
1112	LT1112S8	LT	dOA	$V_{OS} < 60\text{ мкВ}; V_{OD} = \pm 15\text{ В}; I_S < 400\text{ мкА}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • -IN B • -IN B • OUT B • V+
11121	LT1112S8	LT	dOA	$V_{OS} < 60\text{ мкВ}; V_{OD} = \pm 15\text{ В}; I_S < 400\text{ мкА}; T_{AMB}=-40...85\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • -IN B • -IN B • OUT B • V+
1113	LT1113CS8	LT	dOA	JFET; $V_{OS} < 1.5\text{ мВ}; V_{OD} = \pm 15\text{ В}; I_S < 6.5\text{ мА}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • -IN B • -IN B • OUT B • V+
1116	LT1116CS8	LT	cmp	$V_{OS} < 3.5\text{ мВ}; V_{OD} = 5/\pm 5\text{ В}; f_{PD} = 12\text{ нс}; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	V+ • -IN • -IN • V- • LAT ENBL • GND • Q OUT • Q OUT
1118	LT1118CS8	LT	reg	LDO; $V_{IN} < 15\text{ В}; I_{OUT} = 800\text{ мА}$	SOP-8	GND • n.c. • EN • FB • IN • OUT • IN • GND
111825	LT1118CS8-2.5	LT	reg	LDO; $V_{IN} < 15\text{ В}; V_{OUT} = 2.5\text{ В}; I_{OUT} = 800\text{ мА}$	SOP-8	IN • OUT • GND • IN • n.c. • GND • GND • EN
111828	LT1118CS8-2.85	LT	reg	LDO; $V_{IN} < 15\text{ В}; V_{OUT} = 2.85\text{ В}; I_{OUT} = 800\text{ мА}$	SOP-8	IN • OUT • GND • IN • n.c. • GND • GND • EN
11185	LT1118CS8-5	LT	reg	LDO; $V_{IN} < 15\text{ В}; V_{OUT} = 5\text{ В}; I_{OUT} = 800\text{ мА}$	SOP-8	IN • OUT • GND • IN • n.c. • GND • GND • EN
1128	LT1128CS8	LT	OA	$V_{OS} < 40\text{ мкВ}; V_{OD} = \pm 15\text{ В}; I_S < 10.5\text{ мА}; T_{AMB}=-40...85\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	VOSTRIM • -IN • -IN • V- • OVER COMP • OUT • V+ • VOSTRIM
1905	LT1019CS8-5	LT	vref	$V_{OUT} = 5\text{ В}; \text{ACC} < 0.2\%; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
1910	LT1019CS8-10	LT	vref	$V_{OUT} = 10\text{ В}; \text{ACC} < 0.2\%; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
1925	LT1019CS8-2.5	LT	vref	$V_{OUT} = 2.5\text{ В}; \text{ACC} < 0.2\%; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
1945	LT1019CS8-4.5	LT	vref	$V_{OUT} = 4.5\text{ В}; \text{ACC} < 0.2\%; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
19A05	LT1019ACS8-5	LT	vref	$V_{OUT} = 5\text{ В}; \text{ACC} < 0.05\%; T_{AMB}=0...70\text{ }^\circ\text{C}$	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.



MSOP-8 **SOT23-8**
SOP-8 **TSOT23-8**

US-8



MSOP-10

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
19A25	LT1019AIS8-2.5	LT	vref	$V_{OUT}=2.5\text{ В}; \text{ACC} < 0.05\%; T_{\text{AMB}} = 0...70^\circ\text{C}$	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
19A105	LT1019AIS8-5	LT	vref	$V_{OUT}=5\text{ В}; \text{ACC} < 0.05\%; T_{\text{AMB}} = -40...85^\circ\text{C}$	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
19A125	LT1019AIS8-2.5	LT	vref	$V_{OUT}=2.5\text{ В}; \text{ACC} < 0.05\%; T_{\text{AMB}} = -40...85^\circ\text{C}$	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
19105	LT1019IS8-5	LT	vref	$V_{OUT}=5\text{ В}; \text{ACC} < 0.2\%; T_{\text{AMB}} = -40...85^\circ\text{C}$	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
19125	LT1019IS8-2.5	LT	vref	$V_{OUT}=2.5\text{ В}; \text{ACC} < 0.2\%; T_{\text{AMB}} = -40...85^\circ\text{C}$	SOP-8	i.c. • INPUT • TEMP • GND • TRIM • OUTPUT • i.c. • i.c.
2105	LT1021DCS8-5	LT	vref	$V_{OUT}=5\text{ В}; T_{\text{AMB}} = 0...70^\circ\text{C}$	SOP-8	i.c. • VIN • i.c. • GND • TRIM • VOUT • i.c. • i.c.
2107	LT1021DCS8-7	LT	vref	$V_{OUT}=7\text{ В}; T_{\text{AMB}} = 0...70^\circ\text{C}$	SOP-8	i.c. • VIN • i.c. • GND • TRIM • VOUT • i.c. • i.c.
2110	LT1021DCS8-10	LT	vref	$V_{OUT}=10\text{ В}; T_{\text{AMB}} = 0...70^\circ\text{C}$	SOP-8	i.c. • VIN • i.c. • GND • TRIM • VOUT • i.c. • i.c.
3401	LT1034CS8-1.2	LT	vref x2	$V_{OUT1}=1.2\text{ В}; V_{OUT2}=7\text{ В}; T_{\text{AMB}} = 0...70^\circ\text{C}$	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • 7V • 2.5V • n.c. • 2.5V
3402	LT1034CS8-2.5	LT	vref x2	$V_{OUT1}=2.5\text{ В}; V_{OUT2}=7\text{ В}; T_{\text{AMB}} = 0...70^\circ\text{C}$	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • 7V • 2.5V • n.c. • 2.5V
34102	LT1034IS8-2.5	LT	vref x2	$V_{OUT1}=2.5\text{ В}; V_{OUT2}=7\text{ В}; T_{\text{AMB}} = -40...85^\circ\text{C}$	SOP-8	n.c. • n.c. • n.c. • GND • 7V • 2.5V • n.c. • 2.5V
37518	MC33375D-1.8	ON	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...13\text{ В}; V_{OUT}=1.8\text{ В}; I_{\text{OUT}}=300\text{ мА}$	SOP-8	IN • GND • GND • ON/OFF • n.c. • GND • GND • OUT
37525	MC33375D-2.5	ON	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...13\text{ В}; V_{OUT}=2.5\text{ В}; I_{\text{OUT}}=300\text{ мА}$	SOP-8	IN • GND • GND • ON/OFF • n.c. • GND • GND • OUT
37530	MC33375D-3.0	ON	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...13\text{ В}; V_{OUT}=3.0\text{ В}; I_{\text{OUT}}=300\text{ мА}$	SOP-8	IN • GND • GND • ON/OFF • n.c. • GND • GND • OUT
37533	MC33375D-3.3	ON	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...13\text{ В}; V_{OUT}=3.3\text{ В}; I_{\text{OUT}}=300\text{ мА}$	SOP-8	IN • GND • GND • ON/OFF • n.c. • GND • GND • OUT
37550	MC33375D-5.0	ON	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...13\text{ В}; V_{OUT}=5.0\text{ В}; I_{\text{OUT}}=300\text{ мА}$	SOP-8	IN • GND • GND • ON/OFF • n.c. • GND • GND • OUT
5812	MRF5812	MOT	npn	$V_{\text{CBO}}=30\text{ В}; I_{\text{c}}=200\text{ мА}; P_{\text{D}}=1670\text{ мВт}; h_{21}=30...200; f_{\text{T}}=5.5\text{ ГГц}$	SOP-8	E • C • C • E • E • B • B • E
5943	MRF5943	MOT	npn	$V_{\text{CBO}}=40\text{ В}; I_{\text{c}}=400\text{ мА}; P_{\text{D}}=1\text{ Вт}; h_{21}=25...200; f_{\text{T}}=1.3\text{ ГГц}$	SOP-8	E • C • C • E • E • B • B • E
A0R	AD8532ARMZ	AD	dOA	$f_{\text{BD}}=3\text{ МГц}; P_{\text{D}}=12\text{ мВт}; V_{\text{DD}}=2.7...6\text{ В}$	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V • -IN B • -IN B • OUT B • V+
A1A	OP777ARIM	AD	OA	$V_{\text{DD}}=2.7...30/\pm 1.35... \pm 15\text{ В}; I_{\text{S}}=320\text{ мкА}; V_{\text{OS}} < 200\text{ мкВ}$	MSOP-8	n.c. • -IN • +IN • V • n.c. • OUT • V+ • n.c.
A34	OPA234EA	TI	OA	$V_{\text{DD}}=2.7...36/\pm 1.35... \pm 18\text{ В}; I_{\text{S}}=300\text{ мкА}; V_{\text{OS}} < \pm 350\text{ мкВ}$	MSOP-8	OFF TRIM • -IN • +IN • V • OFF TRIM • OUT • V+ • n.c.
A4	NLAS323US	ON	asw	2x SPST; $R_{\text{ON}} < 55\text{ Ом}; V_{\text{DD}}=2.7...6.0\text{ В}$	US-8	NO1 • COM1 • IN2 • GND • NO2 • COM2 • IN1 • VCC
A40A	OPA2340EA	TI	dOA	R-R; $V_{\text{DD}}=2.7...5.5\text{ В}; f_{\text{BD}}=5.5\text{ МГц}; I_{\text{S}}=1.1\text{ мА}; V_{\text{OS}} < \pm 0.5\text{ мВ}$	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V • -IN B • -IN B • OUT B • V+
A44	OPA2244EA	TI	dOA	R-R; $V_{\text{DD}}=2.2...36/\pm 1.1... \pm 18\text{ В}; I_{\text{S}}=70\text{ мкА}; V_{\text{OS}} < \pm 2\text{ мВ}$	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V • -IN B • -IN B • OUT B • V+
A5A	AD8529ARU	AD	dOA	$f_{\text{BD}}=8\text{ МГц}; P_{\text{D}}=24\text{ мВт}; V_{\text{DD}}=2.7...12\text{ В}$	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V • -IN B • -IN B • OUT B • V+
A7	OPA2337EA	TI	dOA	R-R; $V_{\text{DD}}=2.5...5.5\text{ В}; f_{\text{BD}}=3\text{ МГц}; I_{\text{S}}=2\text{ мА}; V_{\text{OS}} < \pm 3.5\text{ мВ}$	SOT23-8	OUT A • -IN A • +IN A • V • -IN B • -IN B • OUT B • V+
A8	OPA2338EA	TI	dOA	R-R; $V_{\text{DD}}=2.5...5.5\text{ В}; f_{\text{BD}}=12.5\text{ МГц}; I_{\text{S}}=2\text{ мА}; V_{\text{OS}} < \pm 3.5\text{ мВ}$	SOT23-8	OUT A • -IN A • +IN A • V • +IN B • -IN B • OUT B • V+
AAAA	MAX1792EUA18	MAX	reg	LDO; $V_{\text{IN}}=2.5...5.5\text{ В}; V_{\text{OUT}}=1.8/1.25...5.5\text{ В}; I_{\text{OUT}}=500\text{ мА}$	MSOP-8	IN • IN • RST • SHDN • GND • SET • OUT • OUT
AAAA	MAX4451EKA	MAX	dOA	R-R; $V_{\text{DD}}=4.5...11/\pm 2.25... \pm 5.5\text{ В}; f_{\text{BD}}=210\text{ МГц}; V_{\text{OS}} < 26\text{ мВ}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VEE • INB+ • -INB • -OUTB • VCC

MSOP-10



US-8

SOT23-8
TSOT23-8MSOP-8
SOP-8

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
AAAB	MAX1792EUA25	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5 \dots 5.5$ В; $V_{OUT} = 2.5/1.25 \dots 5$ В; $I_{OUT} = 500$ мА	MSOP-8	IN•IN•RST•SHDN•GND•SET•OUT•OUTA
AAAB	MAX4453EZA	MAX	dIOA	R-R; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.25$ В; $f_{DD} = 200$ МГц; $V_{OS} < 12$ мВ	TSOT23-8	OUTA•INA•INA+•VEE•INB+•INB-•OUTB•VCC
AAAC	MAX1792EUA33	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5 \dots 5.5$ В; $V_{OUT} = 3.3/1.25 \dots 5$ В; $I_{OUT} = 500$ мА	MSOP-8	IN•IN•RST•SHDN•GND•SET•OUT•OUTA
AAAC	MAX5222EKA	MAX	DAC	2x 8-папа; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5$ В	SOT23-8	CS•GND•VDD•SCLK•OUTA•OUTB•REF•DIN
AAAD	MAX1792EUA50	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5 \dots 5.5$ В; $V_{OUT} = 5.0/1.25 \dots 5$ В; $I_{OUT} = 500$ мА	MSOP-8	IN•IN•RST•SHDN•GND•SET•OUT•OUTA
AAAD	MAX9077EKA	MAX	cmp x2	R-R; $V_{OS} < \pm 8$ мВ; $V_{CC} = 2.1 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 13$ мкА	SOT23-8	OUTA•GND•INA•INA+•INB+•INB-•OUTB•VCC
AAAE	MAX1792EUA15	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5 \dots 5.5$ В; $V_{OUT} = 1.5/1.25 \dots 5$ В; $I_{OUT} = 500$ мА	MSOP-8	IN•IN•RST•SHDN•GND•SET•OUT•OUTA
AAAE	MAX4541EKA	MAX	asw	2x SPST; $R_{ON} < 75$ Ом; $V_{DD} = 2.7 \dots 12$ В	SOT23-8	NO1•V+•IN2•COM2•NO2•GND•IN1•COM1
AAAF	MAX1792EUA20	MAX	reg	LDO; $V_{IN} = 2.5 \dots 5.5$ В; $V_{OUT} = 2.0/1.25 \dots 5$ В; $I_{OUT} = 500$ мА	MSOP-8	IN•IN•RST•SHDN•GND•SET•OUT•OUTA
AAAF	MAX4542EKA	MAX	asw	2x SPST; $R_{ON} < 75$ Ом; $V_{DD} = 2.7 \dots 12$ В	SOT23-8	NC1•V+•IN2•COM2•NC2•GND•IN1•COM1
AAAG	MAX4543EKA	MAX	asw	2x SPST; $R_{ON} < 75$ Ом; $V_{DD} = 2.7 \dots 12$ В	SOT23-8	NO1•V+•IN2•COM2•NC2•GND•IN1•COM1
AAAH	MAX6365LKA46	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAI	MAX6365LKA44	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAJ	MAX6365LKA31	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAK	MAX6365LKA29	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAL	MAX6365LKA26	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAM	MAX6365LKA23	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAN	MAX6365PKA46	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAO	MAX6365PKA44	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAP	MAX6365PKA31	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAQ	MAX6365PKA29	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAR	MAX6365PKA26	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAS	MAX6365PKA23	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAT	MAX6365HKA46	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAU	MAX6365HKA44	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAV	MAX6365HKA31	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAW	MAX6365HKA29	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAX	MAX6365HKA26	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT
AAAY	MAX6365HKA23	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32$ В; $V_{DD} = 1.2 \dots 5.5$ В; $I_{CC} < 50$ мкА	SOT23-8	RESET•CE•IN•GND•MR•VCC•OUT•BATT•CE•OUT

MSOP-10



US-8

SOT23-8
TSOT23-8MSOP-8
SOP-8

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
AACC	MAX6367PKA23	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACD	MAX6367HKA46	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACE	MAX6367HKA44	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACF	MAX6367HKA31	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACG	MAX6367HKA29	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACH	MAX6367HKA26	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACI	MAX6367HKA23	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • BATT ON • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACJ	MAX6368LKA46	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACK	MAX6368LKA44	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACL	MAX6368LKA31	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACM	MAX6368LKA29	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACN	MAX6368LKA26	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACO	MAX6368LKA23	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACP	MAX6368PKA46	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACQ	MAX6368PKA44	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACR	MAX6368PKA31	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACS	MAX6368PKA29	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACT	MAX6368PKA26	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACU	MAX6368PKA23	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACV	MAX6368HKA46	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACW	MAX6368HKA44	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACX	MAX6368HKA31	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACY	MAX6368HKA29	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AACZ	MAX6368HKA26	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AADA	MAX6368HKA23	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 50\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET • CE IN • GND • RESET IN • VCC • OUT • BATT • CE OUT
AADB	MAX4491AKA	MAX	dOA	$R\text{-}R; V_{DD} = 2.7...5.5/\pm 1.35... \pm 2.75\text{ В}; I_{BO} = 10\text{ мА}; V_{OS} < 16\text{ мВ}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA • VSS • INB • INB • OUTB • VDD
AADC	MAX6369KA	MAX	wdt	$I_{STUP} = 0.001...60\text{ мА}; V_{DD} = 2.5...5.5\text{ В}; I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	WDI • GND • n.c. • SET0 • SET1 • SET2 • WDO • VCC
AADD	MAX6370KA	MAX	wdt	$I_{STUP} = 0.001...60\text{ мА}; V_{DD} = 2.5...5.5\text{ В}; I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	WDI • GND • n.c. • SET0 • SET1 • SET2 • WDO • VCC
AADE	MAX6371KA	MAX	wdt	$I_{STUP} = 60\text{ мА}; V_{DD} = 2.5...5.5\text{ В}; I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	WDI • GND • n.c. • SET0 • SET1 • SET2 • WDO • VCC



MSOP-8 SOT23-8
SOP-8 TSOT23-8 US-8



MSOP-10

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
AADF	MAX6372KA	MAX	wdt	$t_{STUP} = 60\text{c}$; $V_{DD} = 2.5...5.5\text{В}$; $I_{CC} < 20\text{мкА}$	SOT23-8	WDI • GND • n.c. • SET0 • SET1 • SET2 • WDO • VCC
AADG	MAX6373KA	MAX	wdt	$t_{STUP} = 0.0002...60\text{c}$; $V_{DD} = 2.5...5.5\text{В}$; $I_{CC} < 20\text{мкА}$	SOT23-8	WDI • GND • n.c. • SET0 • SET1 • SET2 • WDO • VCC
AADH	MAX6374KA	MAX	wdt	$t_{STUP} = 0.0002...60\text{c}$; $V_{DD} = 2.5...5.5\text{В}$; $I_{CC} < 20\text{мкА}$	SOT23-8	WDI • GND • n.c. • SET0 • SET1 • SET2 • WDO • VCC
AADI	MAX4402AKA	MAX	dOA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5\text{В}$; $f_{BD} = 800\text{кГц}$; $V_{OS} < 5.5\text{мВ}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VSS • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AADK	MAX3314KA	MAX	trans	RS-232; $V_{CC} = \pm 4.75... \pm 5.25\text{В}$; $f_{DR} = 460\text{Кбит/с}$; $I_{CC} < 100\text{мкА}$	SOT23-8	VCC • SHDN • ROUT • TIN • TOUT • RIN • V- • GND
AADL	MAX3314EKA	MAX	trans	RS-232; $V_{CC} = \pm 4.75... \pm 5.25\text{В}$; $f_{DR} = 460\text{Кбит/с}$; $I_{CC} < 100\text{мкА}$	SOT23-8	VCC • SHDN • ROUT • TIN • TOUT • RIN • V- • GND
AADM	MAX1801EKA	MAX	dcdc	$V_{IN} = 2.7...5.5\text{В}$; $V_{REF} = 1.25\text{В}$; $I_{CC} < 300\text{мкА}$	SOT23-8	OSC • GND • REF • DCON • COMP • FB • IN • DL
AADN	MAX9110EKA	MAX	LVDS drv	$V_{DD} = 350\text{мВ}$; $V_{CC} = 3...3.6\text{В}$; $I_{CC} < 8\text{мА}$	SOT23-8	DIN • GND • n.c. • VCC • n.c. • n.c. • DO+ • DO-
AADO	MAX9112EKA	MAX	LVDS drv x2	$V_{DD} = 350\text{мВ}$; $V_{CC} = 3...3.6\text{В}$; $I_{CC} < 13\text{мА}$	SOT23-8	DIN1 • GND • DIN2 • VCC • DO2- • DO2+ • DO1+ • DO1-
AADR	MAX4413EKA	MAX	dOA	R-R; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{В}$; $f_{BD} = 500\text{МГц}$; $V_{OS} < 9\text{мВ}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AADS	MAX4453EKA	MAX	dOA	R-R; $V_{DD} = 2.7...5.25\text{В}$; $f_{BD} = 200\text{МГц}$; $V_{OS} < 12\text{мВ}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AADT	MAX4353EKA	MAX	dOA	R-R; $V_{DD} = 2.7...5.25\text{В}$; $f_{BD} = 80\text{МГц}$; $V_{OS} < 12\text{мВ}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AADU	MAX1115EKA	MAX	ADC	8-папп; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7...3.6\text{В}$	SOT23-8	VDD • CH0 • i.c. • GND • i.c. • CONVST • DOUT • SCLK
AADV	MAX1116EKA	MAX	ADC	8-папп; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 4.5...5.5\text{В}$	SOT23-8	VDD • CH0 • i.c. • GND • i.c. • CONVST • DOUT • SCLK
AADW	MAX1117EKA	MAX	ADC	2x8-папп; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7...3.6\text{В}$	SOT23-8	VDD • CH0 • CH1 • GND • (REF) • i.c. • CNVST • DOUT • SCLK
AADX	MAX1118EKA	MAX	ADC	2x8-папп; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{В}$	SOT23-8	VDD • CH0 • CH1 • GND • (REF) • i.c. • CNVST • DOUT • SCLK
AADY	MAX1119EKA	MAX	ADC	2x8-папп; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 4.5...5.5\text{В}$	SOT23-8	VDD • CH0 • CH1 • GND • (REF) • i.c. • CNVST • DOUT • SCLK
AADZ	MAX989EKA	MAX	cmp x2	R-R; $V_{OS} \leq \pm 7\text{мВ}$; $V_{CC} = 2.5...5.5\text{В}$; $I_{CC} < 48\text{мкА}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAEA	MAX990EKA	MAX	cmp x2	R-R; $V_{OS} \leq \pm 7\text{мВ}$; $V_{CC} = 2.5...5.5\text{В}$; $I_{CC} < 48\text{мкА}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAEB	MAX991EKA	MAX	cmp x2	R-R; $V_{OS} \leq \pm 7\text{мВ}$; $V_{CC} = 2.5...5.5\text{В}$; $I_{CC} < 190\text{мкА}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAEC	MAX992EKA	MAX	cmp x2	R-R; $V_{OS} \leq \pm 7\text{мВ}$; $V_{CC} = 2.5...5.5\text{В}$; $I_{CC} < 190\text{мкА}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VEE • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAED	MAX9113EKA	MAX	LVDS drv x2	$V_{OH} > 2.7\text{В}$; $V_{OL} < 0.4\text{В}$; $V_{CC} = 3...3.6\text{В}$; $I_{CC} < 11\text{мА}$	SOT23-8	VCC • GND • OUT1 • OUT2 • IN2- • IN2+ • IN1+ • IN1-
AAEE	MAX9111EKA	MAX	LVDS drv	$V_{OH} > 2.7\text{В}$; $V_{OL} < 0.4\text{В}$; $V_{CC} = 3...3.6\text{В}$; $I_{CC} < 6\text{мА}$	SOT23-8	VCC • GND • OUT • n.c. • n.c. • n.c. • IN+ • IN1-
AAEF	MAX9032AKA	MAX	cmp x2	R-R; $V_{OS} \leq \pm 5\text{мВ}$; $V_{DD} = 2.5...5.5\text{В}$; $f_{BD} < 110\text{мкА}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VSS • INB+ • INB- • OUTB • VDD
AAEG	MAX9022AKA	MAX	cmp x2	R-R; $V_{OS} \leq \pm 8\text{мВ}$; $V_{DD} = 2.5...5.5\text{В}$; $f_{BD} < 10\text{мкА}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VSS • INB+ • INB- • OUTB • VDD
AAEI	MAX4564EKA	MAX	asw	SPDT; $R_{ON} < 100\text{Ом}$; $V_{DD} = 1.8...12/\pm 1.8... \pm 6\text{В}$	SOT23-8	NC • V+ • IN • NO • GND • V- • EN • COM
AAEJ	MAX4482AKA	MAX	dOA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5\text{В}$; $I_{CC} < 100\text{мкА}$; $V_{OS} < 5.5\text{мВ}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VSS • INB+ • INB- • OUTB • VDD
AAEK	MAX4471EKA	MAX	dOA	R-R; $V_{DD} = 1.8...5.5\text{В}$; $f_{BD} = 9\text{кГц}$; $I_{CC} < 1.2\text{мкА}$; $V_{OS} < 7\text{мВ}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VSS • INB+ • INB- • OUTB • VCC
AAEL	MAX4474EKA	MAX	dOA	R-R; $V_{DD} = 1.8...5.5\text{В}$; $f_{BD} = 40\text{кГц}$; $I_{CC} < 1.2\text{мкА}$; $V_{OS} < 7\text{мВ}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VSS • INB+ • INB- • OUTB • VCC

MSOP-10



US-8

SOT23-8
TSOT23-8MSOP-8
SOP-8

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
AAEM	MAX4494AKA	MAX	dOA	R-R; $V_{DD} = \pm 2.25... \pm 5.5$ В; $f_{BD} = 5$ МГц; $V_{OS} < 10$ мВ	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VEE • INB+ • INB • OUTB • VDD
AAEN	MAX5400EKA	MAX	Dpot	256 позиций; 50 кОм; $V_{DD} = 2.7... 5.5$ В	SOT23-8	L • GND • CS • DIN • SCLK • VDD • W • H
AAEO	MAX5401EKA	MAX	Dpot	256 позиций; 100 кОм; $V_{DD} = 2.7... 5.5$ В	SOT23-8	L • GND • CS • DIN • SCLK • VDD • W • H
AAEP	MAX4486AKA	MAX	dOA	R-R; $V_{DD} = 2.7... 5.5$ В; $f_{BD} = 7$ МГц; $V_{OS} < 9$ мВ	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VSS • INB+ • INB • OUTB • VDD
AAEQ	MAX6627MKA	MAX	dts	12-разр.+знак; $T_{AMB} = -55... 125$ °C; SPI; $V_{DD} = 3... 5.5$ В; $I_{CC} = 30$ мкА	SOT23-8	GND • DXN • DXP • VCC • SCK • CS • SO • n.c.
AAER	MAX6628MKA	MAX	dts	12-разр.+знак; $T_{AMB} = -55... 125$ °C; SPI; $V_{DD} = 3... 5.5$ В; $I_{CC} = 200$ мкА	SOT23-8	GND • DXN • DXP • VCC • SCK • CS • SO • n.c.
AAES	MAX5223EKA	MAX	DAC	2×8-разр.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7... 5.5$ В	SOT23-8	CS • GND • VDD • SCLK • OUTA • OUTB • REF • DIN
AAEU	MAX9203EKA	MAX	cmp	$V_{OS} < 7.5$ мВ; $V_{CC} = 4.75... 10.5$ В; $V_{DD} = 4.75... 5.25$ В	SOT23-8	VDD • OUT • GND • LATCH • VEE • IN • IN+ • VCC
AAEV	MAX1087EKA	MAX	ADC	2×10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7... 3.6$ В	SOT23-8	VDD • AIN1 • AIN2 • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAEW	MAX1287EKA	MAX	ADC	2×12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7... 3.6$ В	SOT23-8	VDD • AIN1 • AIN2 • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAEX	MAX1089EKA	MAX	ADC	10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7... 3.6$ В	SOT23-8	VDD • AIN+ • AIN- • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAEY	MAX1289EKA	MAX	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7... 3.6$ В	SOT23-8	VDD • AIN+ • AIN- • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAEZ	MAX1086EKA	MAX	ADC	2×10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 4.5... 5.5$ В	SOT23-8	VDD • AIN1 • AIN2 • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAFA	MAX1286EKA	MAX	ADC	2×12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 4.5... 5.5$ В	SOT23-8	VDD • AIN1 • AIN2 • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAFB	MAX1088EKA	MAX	ADC	10-разр.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 4.5... 5.5$ В	SOT23-8	VDD • AIN+ • AIN- • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAFC	MAX1288EKA	MAX	ADC	12-разр.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 4.5... 5.5$ В	SOT23-8	VDD • AIN+ • AIN- • GND • REF • CNVST • DOUT • SCLK
AAFD	MAX9141EKA	MAX	cmp	$V_{OS} < 4.5$ мВ; $V_{CC} = 2.7... 5.5$ В; $I_{CC} < 300$ мкА	SOT23-8	VCC • IN+ • IN- • GND • LE • SHDN • OUT • n.c.
AAFE	MAX9142EKA	MAX	cmp x2	$V_{OS} < 4.5$ мВ; $V_{CC} = 2.7... 5.5$ В; $I_{CC} < 300$ мкА	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • GND • INB+ • INB • OUTB • VCC
AAFF	MAX6705LKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 4.63$ В; $V_{DD} = 1.2... 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFG	MAX6705MKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 4.38$ В; $V_{DD} = 1.2... 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFH	MAX6705RKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 2.63$ В; $V_{DD} = 1.2... 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFI	MAX6705SKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 2.93$ В; $V_{DD} = 1.2... 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFJ	MAX6705TKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 3.08$ В; $V_{DD} = 1.2... 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFK	MAX6705YKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 2.19$ В; $V_{DD} = 1.2... 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFL	MAX6705ZKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 2.32$ В; $V_{DD} = 1.2... 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFM	MAX6706LKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 4.63$ В; $V_{DD} = 1.2... 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFN	MAX6706MKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 4.38$ В; $V_{DD} = 1.2... 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFO	MAX6706RKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 2.63$ В; $V_{DD} = 1.2... 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFP	MAX6706SKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 2.93$ В; $V_{DD} = 1.2... 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO
AAFQ	MAX6706TKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 3.08$ В; $V_{DD} = 1.2... 5.5$ В; $I_{CC} < 20$ мкА	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • WDO

MSOP-10



US-8

SOT23-8
TSOT23-8MSOP-8
SOP-8

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
AAGV	MAX6703LKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 4.63\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGW	MAX6703MKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 4.38\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGX	MAX6703RKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 2.63\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGY	MAX6703SKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 2.93\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAGZ	MAX6703TKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 3.08\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAHA	MAX6703YKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 2.19\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAHB	MAX6703ZKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 2.32\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	MR • VCC • GND • RST_IN1 • RST_IN2 • WDI • RESET • WDO
AAHC	MAX6704LKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 4.63\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • RESET
AAHD	MAX6704MKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 4.38\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • RESET
AAHE	MAX6704RKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 2.63\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • RESET
AAHF	MAX6704SKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 2.93\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • RESET
AAHG	MAX6704TKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 3.08\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • RESET
AAHG	MAX9052AEUA	MAX	cmp x2 + wref	R-R; $V_{DD} < \pm 7\text{ мВ}$; $V_{CC} = 2.7...5.5\text{ В}$; $V_{REF} = 2.500\text{ В}$; $I_{CC} < 72\text{ мкА}$	MSOP-8	OUTA • REF • INA • VEE • INB • INB • OUTB • VCC
AAHN	MAX6704YKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 2.19\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • RESET
AAHI	MAX6704ZKA	MAX	mrc + wdt	$V_{TR} = 2.32\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 20\text{ мкА}$	SOT23-8	MR • VCC • GND • PFI • PFO • WDI • RESET • RESET
AAHI	MAX9052BEUA	MAX	cmp x2 + wref	R-R; $V_{DD} < \pm 7\text{ мВ}$; $V_{CC} = 2.7...5.5\text{ В}$; $V_{REF} = 2.500\text{ В}$; $I_{CC} < 72\text{ мкА}$	MSOP-8	OUTA • REF • INA • VEE • INB • INB • OUTB • VCC
AAHU	MAX6391KA46	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHK	MAX6391KA44	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHL	MAX6391KA31	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHM	MAX6391KA29	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHN	MAX6391KA26	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHO	MAX6391KA23	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHP	MAX6391KA22	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.19\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHQ	MAX6391KA17	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.67\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHR	MAX6391KA16	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.58\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • R1
AAHS	MAX6392KA46	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.63\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAHT	MAX6392KA44	MAX	mrc	$V_{TR} = 4.38\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAHU	MAX6392KA31	MAX	mrc	$V_{TR} = 3.08\text{ В}$; $V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}$; $I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR



MSOP-8 **SOT23-8**
SOP-8 **TSOT23-8** **US-8**



MSOP-10

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
AAHV	MAX6392KA29	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.93\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAHW	MAX6392KA26	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAHX	MAX6392KA23	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAHY	MAX6392KA22	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.19\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAHZ	MAX6392KA17	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.67\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAIA	MAX6392KA16	MAX	mrc	$V_{TR} = 1.58\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 25\text{ мкА}$	SOT23-8	RESET IN2 • VCC • CSRT • GND • RESET2 • R2 • RESET1 • MR
AAIB	MAX9107EKA	MAX	cmp x2	$V_{OSI} < 4\text{ мВ}; V_{CC} = 4.5...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.4\text{ мА}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • GND • INB • INB- OUTB • VCC
AAIC	MAX4351EKA	MAX	dOA	R-R; $V_{DD} = \pm 4.5...5.5\text{ В}; f_{BD} = 210\text{ МГц}; V_{OSI} < 26\text{ мВ}$	SOT23-8	OUTA • INA • INA+ • VEE • INB+ • INB- OUTB • VCC
AAID	MAX5407EKA	MAX	Dpot	32 позиции; логарифм; 20 кОм; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	SOT23-8	H • GND • W • L • U • D • CS • VDD • ZCEN
AAIE	MAX4649EKA	MAX	asw	SPDT; $R_{ON} < 60\text{ Ом}; V_{DD} = 9...36/\pm 4.5... \pm 20\text{ В}$	SOT23-8	COM • NC • GND • V+ • n.c. • IN • V • NO
ABA	AD8602ARM	AD	dOA	$f_{BD} = 8\text{ МГц}; P_D = 12\text{ мВт}; V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+
ABD	AD8602DRM	AD	dOA	$f_{BD} = 8\text{ МГц}; P_D = 12\text{ мВт}; V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+
AFA	AD8527ARM	AD	dOA	$f_{BD} = 7\text{ МГц}; P_D = 12\text{ мВт}; V_{DD} = 1.8...6\text{ В}$	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+
AGA	AD8632ARM	AD	dOA	$f_{BD} = 5\text{ МГц}; P_D = 6\text{ мВт}; V_{DD} = 1.8...6\text{ В}$	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+
AHA	AD8551ARM	AD	OA	$f_{BD} = 1.5\text{ МГц}; P_D = 5\text{ мВт}; V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	MSOP-8	n.c. • -IN A • +IN A • V- • n.c. • OUT A • V+ • n.c.
AJA	AD8571ARM	AD	OA	$f_{BD} = 1.5\text{ МГц}; P_D = 5\text{ мВт}; V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	MSOP-8	n.c. • -IN A • +IN A • V- • n.c. • OUT A • V+ • n.c.
AK	SSM2250RM	AD	amp	$V_{CC} = 2.7...6\text{ В}; I_{CC} = 6.4\text{ мА}; P_{OUT} = 1.5\text{ Вт (моно)}/0.25\text{ Вт (стерео)}; f_{BD} = 4\text{ МГц}$	MSOP-10	IN • SHDN • SE/BTL • GND • R • IN • R OUT • BPS • BTL • VDD • L • OUT/BTL-
AK#	SSM2250RMZ	AD	amp	$V_{CC} = 2.7...6\text{ В}; I_{CC} = 6.4\text{ мА}; P_{OUT} = 1.5\text{ Вт (моно)}/0.25\text{ Вт (стерео)}; f_{BD} = 4\text{ МГц}$	MSOP-10	IN • SHDN • SE/BTL • GND • R • IN • R OUT • BPS • BTL • VDD • L • OUT/BTL-
AKG	TLV2632IDGK	TI	dOA	R-R; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}; f_{BD} = 9\text{ МГц}; V_{OSI} < 4.5\text{ мВ}$	MSOP-8	OUT1 • IN1 • IN1+ • GND • IN2+ • IN2 • OUT2 • VDD
AKK	TLV2633IDGS	TI	dOA	R-R; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}; f_{BD} = 9\text{ МГц}; V_{OSI} < 4.5\text{ мВ}$	MSOP-10	OUT1 • IN1 • IN1+ • GND • SHDN1 • SHDN2 • IN2+ • IN2 • OUT2 • VDD
AND	OP162DRM	AD	OA	R-R; $V_{DD} = 2.7...12\text{ В}; f_{BD} = 15\text{ МГц}; I_S = 850\text{ мкА}; V_{OSI} < 325\text{ мкВ}$	MSOP-8	NULL • -IN • +IN • V- • n.c. • OUT • V+ • NULL
AOB	THS4130CDGN	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{ В}; f_{BD} = 150\text{ МГц}; V_{OSI} < 3\text{ мВ}$	MSOPPo werPAD-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • PD • VIN+
AOC	THS4130IDGN	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{ В}; f_{BD} = 150\text{ МГц}; V_{OSI} < 3\text{ мВ}$	MSOPPo werPAD-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • PD • VIN+
AOD	THS4131CDGN	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{ В}; f_{BD} = 150\text{ МГц}; V_{OSI} < 3\text{ мВ}$	MSOPPo werPAD-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • n.c. • VIN+
AOE	THS4131IDGN	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{ В}; f_{BD} = 150\text{ МГц}; V_{OSI} < 3\text{ мВ}$	MSOPPo werPAD-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • n.c. • VIN+
AOF	THS4140CDGN	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{ В}; f_{BD} = 160\text{ МГц}; V_{OSI} < 8.5\text{ мВ}$	MSOPPo werPAD-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • PD • VIN+
AOG	THS4140IDGN	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{ В}; f_{BD} = 160\text{ МГц}; V_{OSI} < 8.5\text{ мВ}$	MSOPPo werPAD-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • PD • VIN+
AOI	THS4141CDGN	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{ В}; f_{BD} = 160\text{ МГц}; V_{OSI} < 8.5\text{ мВ}$	MSOPPo werPAD-8	VIN • VOCM • VCC+ • VOUT+ • VOUT • VCC • n.c. • VIN+
AOJ	OP162DRMZ	AD	OA	R-R; $V_{DD} = 2.7...12\text{ В}; f_{BD} = 15\text{ МГц}; I_S = 850\text{ мкА}; V_{OSI} < 325\text{ мкВ}$	MSOP-8	NULL • -IN • +IN • V- • n.c. • OUT • V+ • NULL

MSOP-10



US-8

SOT23-8
TSOT23-8MSOP-8
SOP-8

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
AOK	THS4141IDGN	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{В}$; $f_{80} = 160\text{МГц}$; $V_{OS} < 8.5\text{мВ}$	MSOP8-PowerPAD-8	VIN•VOCM•VCC+•VOUT+•VOUT• VCC•n.c.•VIN+
AQA	AD8592ARM	AD	dOA	$f_{80} = 2.2\text{МГц}$; $P_D = 14\text{мВт}$; $V_{DD} = 2.5...6\text{В}$	MSOP-10	OUT A•-IN A•+IN A•V•-SDA•SDB•+IN B•-IN B•OUT B•V+
ARA	AD8532ARM	AD	dOA	$f_{80} = 3\text{МГц}$; $P_D = 12\text{мВт}$; $V_{DD} = 2.7...6\text{В}$	MSOP-8	OUT A•-IN A•+IN A•V•-+IN B•-IN B• OUT B•V+
ASO	THS4130IDGK	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{В}$; $f_{80} = 150\text{МГц}$; $V_{OS} < 3\text{мВ}$	MSOP-8	VIN•VOCM•VCC+•VOUT+•VOUT• VCC•PD•VIN+
ASP	THS4131IDGK	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{В}$; $f_{80} = 150\text{МГц}$; $V_{OS} < 3\text{мВ}$	MSOP-8	VIN•VOCM•VCC+•VOUT+•VOUT• VCC•n.c.•VIN+
ASQ	THS4140IDGK	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{В}$; $f_{80} = 160\text{МГц}$; $V_{OS} < 8.5\text{мВ}$	MSOP-8	VIN•VOCM•VCC+•VOUT+•VOUT• VCC•PD•VIN+
ASR	THS4141IDGK	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{В}$; $f_{80} = 160\text{МГц}$; $V_{OS} < 8.5\text{мВ}$	MSOP-8	VIN•VOCM•VCC+•VOUT+•VOUT• VCC•n.c.•VIN+
ATA	AD8566ARM	AD	dOA	$f_{80} = 5\text{МГц}$; $P_D = 24\text{мВт}$; $V_{DD} = 4.5...16\text{В}$	MSOP-8	OUT A•-IN A•+IN A•V•-+IN B•-IN B• OUT B•V+
ATA#	AD8566ARMZ	AD	dOA	$f_{80} = 5\text{МГц}$; $P_D = 24\text{мВт}$; $V_{DD} = 4.5...16\text{В}$	MSOP-8	OUT A•-IN A•+IN A•V•-+IN B•-IN B• OUT B•V+
ATP	THS4130CDGK	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{В}$; $f_{80} = 150\text{МГц}$; $V_{OS} < 3\text{мВ}$	MSOP-8	VIN•VOCM•VCC+•VOUT+•VOUT• VCC•PD•VIN+
ATQ	THS4131CDGK	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{В}$; $f_{80} = 150\text{МГц}$; $V_{OS} < 3\text{мВ}$	MSOP-8	VIN•VOCM•VCC+•VOUT+•VOUT• VCC•n.c.•VIN+
ATR	THS4140CDGK	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{В}$; $f_{80} = 160\text{МГц}$; $V_{OS} < 8.5\text{мВ}$	MSOP-8	VIN•VOCM•VCC+•VOUT+•VOUT• VCC•PD•VIN+
ATS	THS4141CDGK	TI	DA	$V_{DD} = 5...30/2.5... \pm 15\text{В}$; $f_{80} = 160\text{МГц}$; $V_{OS} < 8.5\text{мВ}$	MSOP-8	VIN•VOCM•VCC+•VOUT+•VOUT• VCC•n.c.•VIN+
AVA	AD8542ARM	AD	dOA	$f_{80} = 1\text{МГц}$; $P_D = 0.6\text{мВт}$; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{В}$	MSOP-8	OUT A•-IN A•+IN A•V•-+IN B•-IN B• OUT B•V+
AZA	OP1177ARM	AD	OA	$V_{DD} = \pm 2.5... \pm 15\text{В}$; $I_S = 600\text{мкА}$; $V_{OS} < 60\text{мкВ}$	MSOP-8	n.c.•-IN•+IN•V•-n.c.•OUT•V+•n.c.
B03	OPA2703EA	TI	dOA	R-R; $V_{DD} = 4...12/\pm 2... \pm 6\text{В}$; $f_{80} = 1\text{МГц}$; $I_S = 300\text{мкА}$; $V_{OS} < \pm 0.75\text{мВ}$	MSOP-8	OUT A•-IN A•+IN A•V•-+IN B•-IN B• OUT B•V+
B04	OPA2704EA	TI	dOA	R-R; $V_{DD} = 4...12/\pm 2... \pm 6\text{В}$; $f_{80} = 3\text{МГц}$; $I_S = 300\text{мкА}$; $V_{OS} < \pm 0.75\text{мВ}$	MSOP-8	OUT A•-IN A•+IN A•V•-+IN B•-IN B• OUT B•V+
B05	OPA2705EA	TI	dOA	R-R; $V_{DD} = 4...12/\pm 2... \pm 6\text{В}$; $f_{80} = 1\text{МГц}$; $I_S = 250\text{мкА}$; $V_{OS} < \pm 5\text{мВ}$	MSOP-8	OUT A•-IN A•+IN A•V•-+IN B•-IN B• OUT B•V+
B0A	AD8610ARM	AD	OA	$f_{80} = 25\text{МГц}$; $P_D = 40\text{мВт}$; $V_{DD} = \pm 5... \pm 13\text{В}$	MSOP-8	NULL•-IN•+IN•V•-NULL•OUT•V+• n.c.
B10	AD5220BRM-10	AD	Dpot	128 позиций; 10 кОм	MSOP-8	CLK•U/D•A1•GND•W1•B1•CS•VDD
B100	AD5220BRM-100	AD	Dpot	128 позиций; 100 кОм	MSOP-8	CLK•U/D•A1•GND•W1•B1•CS•VDD
B26	INA326	BB/ТИ	IA	R-R; $V_{OS} = 100\text{мкВ}$; $V_{DD} = 2.7...5\text{В}$	MSOP-8	R1•VIN•VIN•V•V+•R2•VO•V+•R1
B27	INA327	BB/ТИ	IA	R-R; $V_{OS} = 100\text{мкВ}$; $V_{DD} = 2.7...5\text{В}$; блокировка	MSOP-10	R1•VIN•VIN•V•V+•ENBL•R2•VO• V+•R1
B2A	OP2177ARM	AD	dOA	$V_{DD} = \pm 2.5... \pm 15\text{В}$; $I_S = 1.2\text{мА}$; $V_{OS} < 60\text{мкВ}$	MSOP-8	OUT A•-IN A•+IN A•V•-+IN B•-IN B• OUT B•V+
B36	OPA2336EA	TI	dOA	R-R; $V_{DD} = 2.3...5.5\text{В}$; $I_S = 85\text{мкА}$; $V_{OS} < \pm 125\text{мкВ}$	MSOP-8	OUT A•-IN A•+IN A•V•-+IN B•-IN B• OUT B•V+
B47	OPA2347EA	TI	dOA	R-R; $V_{DD} = 2.3...5.5\text{В}$; $f_{80} = 350\text{кГц}$; $I_S = 80\text{мкА}$; $V_{OS} < 7\text{мВ}$	SOT23-8	OUT A•-IN A•+IN A•V•-+IN B•-IN B• OUT B•V+
B48	OPA2348AI	TI	dOA	R-R; $V_{DD} = 2.1...5.5\text{В}$; $f_{80} = 1\text{МГц}$; $I_S = 150\text{мкА}$; $V_{OS} < 6\text{мВ}$	SOT23-8	OUT A•-IN A•+IN A•V•-+IN B•-IN B• OUT B•V+
B4A	AD822ARM	AD	dOA	$f_{80} = 1.8\text{МГц}$; $P_D = 50\text{мВт}$; $V_{DD} = 3...36/\pm 1.3... \pm 18\text{В}$	MSOP-8	OUT1•-IN1•+IN1•V•-+IN2•-IN2• OUT2•V+
B50	AD5220BRM-50	AD	Dpot	128 позиций; 50 кОм	MSOP-8	CLK•U/D•A1•GND•W1•B1•CS•VDD
B6A	AD8606ARM	AD	dOA	$f_{80} = 10\text{МГц}$; $P_D = 14\text{мВт}$; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{В}$	MSOP-8	OUT A•-IN A•+IN A•V•-+IN B•-IN B• OUT B•V+
B6A#	AD8606ARMZ	AD	dOA	$f_{80} = 10\text{МГц}$; $P_D = 14\text{мВт}$; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{В}$	MSOP-8	OUT A•-IN A•+IN A•V•-+IN B•-IN B• OUT B•V+
B7A	AD8510ARM	AD	OA	$f_{80} = 8\text{МГц}$; $P_D = 70\text{мВт}$; $V_{DD} = \pm 5... \pm 15\text{В}$	MSOP-8	n.c.•-IN•+IN•V•-n.c.•OUT•V+•n.c.



MSOP-8 SOT23-8 US-8
SOP-8 TSOT23-8



MSOP-10

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
B8A	AD8512ARM	AD	dOA	$f_{90} = 8 \text{ МГц}$; $P_D = 70 \text{ мВт}$; $V_{DD} = \pm 5 \dots \pm 15 \text{ В}$	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+
BHK	OPA2363AI	TI	dOA	R-R; $V_{DD} = 1.8 \dots 5.5 \text{ В}$; $f_{90} = 7 \text{ МГц}$; $I_S = 1.4 \text{ mA}$; $V_{OS} < 0.9 \text{ мВ}$	MSOP-10	OUT A • -IN A • +IN A • V- • ENL A • ENL B • +IN B • -IN B • OUT B • V+
BHL	OPA2364AI	TI	dOA	R-R; $V_{DD} = 1.8 \dots 5.5 \text{ В}$; $f_{90} = 7 \text{ МГц}$; $I_S = 1.4 \text{ mA}$; $V_{OS} < 0.9 \text{ мВ}$	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+
BJA	AD8626ARM	AD	dOA	$f_{90} = 5 \text{ МГц}$; $P_D = 50 \text{ мВт}$; $V_{DD} = 5 \dots 26 \pm 2.5 \dots \pm 13 \text{ В}$	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+
C1Y	AD7810YRM	AD	ADC	10-паар.; послед. интерфейс; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	CONVST • VIN+ • VIN- • GND • VREF • DOUT • SCLK • VDD
C2T	AD7466BRMZ	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 1.6 \dots 3.6 \text{ В}$	MSOP-8	CS • SDATA • SCLK • n.c. • n.c. • VIN • GND • VDD
C2Y	AD7823YRM	AD	ADC	8-паар.; I ² C; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	CONVST • VIN+ • VIN- • GND • VREF • DOUT • SCLK • VDD
C3A	AD7818ARM	AD	ADC	10-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	CONVST • OTI • GND • VIN • VDD • DIN/OUT • SCLK • RD/WR
C3B	AD7495ARMZ	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.25 \text{ В}$	MSOP-8	REF OUT • VIN • GND • SCLK • SDATA • VDRIVE • CS • VDD
C3C	AD7475BRMZ	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.25 \text{ В}$	MSOP-8	REF IN • VIN • GND • SCLK • SDATA • VDRIVE • CS • VDD
C43	OPA2343EA	TI	dOA	R-R; $V_{DD} = 2.5 \dots 5.5 \text{ В}$; $f_{90} = 5.5 \text{ МГц}$; $I_S = 2.7 \text{ mA}$; $V_{OS} < \pm 8 \text{ мВ}$	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+
C4A	AD7816ARM	AD	dts	10-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	CONVST • OTI • GND • REFIN • VDD • DIN/OUT • SCLK • RD/WR
C50	OPA350EA	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 \text{ В}$; $f_{90} = 38 \text{ МГц}$; $I_S = 8.5 \text{ mA}$; $V_{OS} < \pm 1 \text{ мВ}$	MSOP-8	n.c. • -IN • +IN • V- • n.c. • OUT • V+ • n.c.
C5A	AD7887ARM	AD	ADC	2x 12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.25 \text{ В}$	MSOP-8	CS • VDD • GND • AIN1/VREF • AIN0 • DIN • DOUT • SCLK
C6A	AD7416ARM	AD	dts	10-паар.; I ² C; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	SDA • SCL • OTI • GND • A2 • A1 • A0 • VDD
C7A	AD7418ARM	AD	ADC	10-паар.; I ² C; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	SDA • SCL • OTI • GND • AIN • REFIN • VDD • CONVST
C8A	AD7475ARM	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.25 \text{ В}$	MSOP-8	REF IN • VIN • GND • SCLK • SDATA • VDRIVE • CS • VDD
C9B	AD7475BRM	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.25 \text{ В}$	MSOP-8	REF IN • VIN • GND • SCLK • SDATA • VDRIVE • CS • VDD
CAA	AD7814ARM	AD	dts	10-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	n.c. • DOUT • CS • SCLK • VDD • DIN • GND • n.c.
CCA	AD7495ARM	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.25 \text{ В}$	MSOP-8	REF OUT • VIN • GND • SCLK • SDATA • VDRIVE • CS • VDD
CCB	AD7495BRM	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.25 \text{ В}$	MSOP-8	REF OUT • VIN • GND • SCLK • SDATA • VDRIVE • CS • VDD
CEW	AD7476AYRM	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.35 \dots 5.25 \text{ В}$	MSOP-8	VDD • SDATA • CS • n.c. • n.c. • SCLK • GND • VIN
CEY	AD7476ABRM	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.35 \dots 5.25 \text{ В}$	MSOP-8	VDD • SDATA • CS • n.c. • n.c. • SCLK • GND • VIN
CFZ	AD7477AARM	AD	ADC	10-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.35 \dots 5.25 \text{ В}$	MSOP-8	VDD • SDATA • CS • n.c. • n.c. • SCLK • GND • VIN
CHA	AD7414ARM	AD	dts	10-паар.; SMBus/I ² C; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	n.c. • SDA • ALERT • SCL • VDD • GND • AS • NC
CHB	AD7414ARM	AD	dts	10-паар.; SMBus/I ² C; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	n.c. • SDA • ALERT • SCL • VDD • GND • AS • NC
CJZ	AD7478AARM	AD	ADC	8-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.35 \dots 5.25 \text{ В}$	MSOP-8	VDD • SDATA • CS • n.c. • n.c. • SCLK • GND • VIN
CKA	AD7314ARM	AD	dts	10-паар.; SPI; $V_{DD} = 2.65 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	n.c. • CE • SCLK • GND • SDO • SDI • ID • VDD
CLB	AD7466BRM	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 1.6 \dots 3.6 \text{ В}$	MSOP-8	CS • SDATA • SCLK • n.c. • n.c. • VIN • GND • VDD
CMB	AD7467BRM	AD	ADC	10-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 1.6 \dots 3.6 \text{ В}$	MSOP-8	CS • SDATA • SCLK • n.c. • n.c. • VIN • GND • VDD

MSOP-10



US-8

SOT23-8
TSOT23-8MSOP-8
SOP-8

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
CNA	AD7466ARM	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; V _{DD} = 1.6...3.6 В	MSOP-8	CS • SDATA • SCLK • n.c. • n.c. • VIN • GND • VDD
CNB	AD7468BRM	AD	ADC	8-паар.; SPI/QSPI/Microwire; V _{DD} = 1.6...3.6 В	MSOP-8	CS • SDATA • SCLK • n.c. • n.c. • VIN • GND • VDD
CNU	AD7468BRMZ	AD	ADC	8-паар.; SPI/QSPI/Microwire; V _{DD} = 1.6...3.6 В	MSOP-8	CS • SDATA • SCLK • n.c. • n.c. • VIN • GND • VDD
CPA	AD7450ARM	AD	ADC	12-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 3...5.5 В	MSOP-8	VREF • VIN • VIN • GND • CS • SDATA • SCLK • VDD
CPB	AD7450BRM	AD	ADC	12-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 3...5.5 В	MSOP-8	VREF • VIN • VIN • GND • CS • SDATA • SCLK • VDD
CQA	AD7680ARM	AD	ADC	16-паар.; SPI/QSPI/Microwire; V _{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-8	VDD • GND • GND • VIN • SCLK • n.c. • SDATA • CS
COB	AD7680BRM	AD	ADC	16-паар.; SPI/QSPI/Microwire; V _{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-8	VDD • GND • GND • VIN • SCLK • n.c. • SDATA • CS
CUB	AD7920BRM	AD	ADC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; V _{DD} = 2.35...5.25 В	MSOP-8	VDD • SDATA • CS • n.c. • n.c. • SCLK • GND • VIN
CWA	AD7910ARM	AD	ADC	10-паар.; SPI/QSPI/Microwire; V _{DD} = 2.35...5.25 В	MSOP-8	VDD • SDATA • CS • n.c. • n.c. • SCLK • GND • VIN
D13E	DAC7513E	TI	DAC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; V _{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	VDD • VREF • VFB • VOUT • SYNC • SCLK • DIN • GND
D13N	DAC7513N	TI	DAC	12-паар.; SPI/QSPI/Microwire; V _{DD} = 2.7...5.5 В	SOT23-8	VOUT • VFB • VREF • VDD • GND • DIN • SCLK • SYNC
D1B	AD7303BRM	AD	DAC	2x8-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	VOUTA • VDD • GND • REF • SCLK • DIN • SYNC • VOUTB
D1P	AD5425YRM	AD	DAC	8-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	IOUT1 • IOUT2 • GND • SCLK • SDIN • SYNC • LDAC • VDD • VREF • RFB
D1Q	AD5426YRM	AD	DAC	8-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 3...5.5 В	MSOP-10	IOUT1 • IOUT2 • GND • SCLK • SDIN • SYNC • SDO • VDD • VREF • RFB
D1R	AD5432YRM	AD	DAC	10-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 3...5.5 В	MSOP-10	IOUT1 • IOUT2 • GND • SCLK • SDIN • SYNC • SDO • VDD • VREF • RFB
D1S	AD5443YRM	AD	DAC	12-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 3...5.5 В	MSOP-10	IOUT1 • IOUT2 • GND • SCLK • SDIN • SYNC • SDO • VDD • VREF • RFB
D22	OPA2822E	TI	дОА	V _{DD} = 5...12 В; I _{DD} = 100 мА; I _S = 10.4 мА; V _{OS} < ±1.6 мВ	SOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+
D2B	AD5300BRM	AD	DAC	8-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	VDD • n.c. • n.c. • VOUT • SYNC • SCLK • DIN • GND
D3B	AD5310BRM	AD	DAC	10-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	VDD • n.c. • n.c. • VOUT • SYNC • SCLK • DIN • GND
D4B	AD5320BRM	AD	DAC	12-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 2.7...5.5 В	MSOP-8	VDD • n.c. • n.c. • VOUT • SYNC • SCLK • DIN • GND
D50	OPA2350EA	TI	дОА	R-R; V _{DD} = 2.7...5.5 В; I _{DD} = 38 мА; I _S = 8.5 мА; V _{OS} < ±1 мВ	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+
D55	OPA2350DGS	TI	дОА	R-R; V _{DD} = 2.7...5.5 В; I _{DD} = 200 мА; I _S = 14 мА; V _{OS} < ±15 мВ	MSOP-10	OUT A • -IN A • +IN A • V- • ENBL A • ENBL B • +IN B • -IN B • OUT B • V+
D5A	AD5302ARM	AD	DAC	2x8-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D5B	AD5302BRM	AD	DAC	2x8-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D6A	AD5312ARM	AD	DAC	2x10-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D6B	AD5312BRM	AD	DAC	2x10-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D6C	AD5322BRMZ	AD	DAC	2x12-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D6T	AD5322ARMZ	AD	DAC	2x12-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D6U	AD5443YRMZ	AD	DAC	12-паар.; SPI/Microwire; V _{DD} = 3...5.5 В	MSOP-10	IOUT1 • IOUT2 • GND • SCLK • SDIN • SYNC • SDO • VDD • VREF • RFB



MSOP-8 **SOT23-8**
SOP-8 **TSOT23-8**

US-8



MSOP-10

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
D6V	AD5432YRMZ	AD	DAC	10-паэр.; SPI/Microwire; V _{DD} =3...5.5 В	MSOP-10	IOUT1 • IOUT2 • GND • SCLK • SDIN • SYNC • SDO • VDD • VREF • RFB
D6W	AD5426YRMZ	AD	DAC	8-паэр.; SPI/Microwire; V _{DD} =3...5.5 В	MSOP-10	IOUT1 • IOUT2 • GND • SCLK • SDIN • SYNC • SDO • VDD • VREF • RFB
D7A	AD5322ARM	AD	DAC	2x12-паэр.; SPI/Microwire; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D7B	AD5322BRM	AD	DAC	2x12-паэр.; SPI/Microwire; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D8B	AD5301BRM	AD	DAC	8-паэр.; I ² C; V _{DD} =2.7...5.5 В	MSOP-8	VDD • A0 • A1 • VOUT • PD • SCL • SDA • GND
D8V	AD5302ARMZ	AD	DAC	2x8-паэр.; SPI/Microwire; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D8W	AD5302BRMZ	AD	DAC	2x8-паэр.; SPI/Microwire; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D8X	AD5312ARMZ	AD	DAC	2x10-паэр.; SPI/Microwire; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D8Y	AD5312BRMZ	AD	DAC	2x10-паэр.; SPI/Microwire; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	LDAC • VDD • VREFB • VREFA • VOUTA • VOUTB • SYNC • SCLK • DIN • GND
D9B	AD5311BRM	AD	DAC	10-паэр.; I ² C; V _{DD} =2.7...5.5 В	MSOP-8	VDD • A0 • A1 • VOUT • PD • SCL • SDA • GND
D9N	AD5320BRMZ	AD	DAC	12-паэр.; SPI/Microwire; V _{DD} =2.7...5.5 В	MSOP-8	VDD • n.c. • n.c. • VOUT • SYNC • SCLK • DIN • GND
DAB	AD5321BRM	AD	DAC	12-паэр.; I ² C; V _{DD} =2.7...5.5 В	MSOP-8	VDD • A0 • A1 • VOUT • PD • SCL • SDA • GND
DBA	AD5304ARM	AD	DAC	4x8-паэр.; SPI/Microwire; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
DBB	AD5304BRM	AD	DAC	4x8-паэр.; SPI/Microwire; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
DCA	AD5314ARM	AD	DAC	4x10-паэр.; SPI/Microwire; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
DCB	AD5314BRM	AD	DAC	4x10-паэр.; SPI/Microwire; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
DDA	AD5324ARM	AD	DAC	4x12-паэр.; SPI/Microwire; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
ddb	AD5324BRM	AD	DAC	4x12-паэр.; SPI/Microwire; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • DIN • SCLK • SYNC
DEA	AD5305ARM	AD	DAC	4x8-паэр.; I ² C; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • SDA • SCL • A0
DEB	AD5305BRM	AD	DAC	4x8-паэр.; I ² C; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • SDA • SCL • A0
DFA	AD5315ARM	AD	DAC	4x10-паэр.; I ² C; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • SDA • SCL • A0
DFB	AD5315BRM	AD	DAC	4x10-паэр.; I ² C; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • SDA • SCL • A0
DGA	AD5325ARM	AD	DAC	4x12-паэр.; I ² C; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • SDA • SCL • A0
DGB	AD5325BRM	AD	DAC	4x12-паэр.; I ² C; V _{DD} =2.5...5.5 В	MSOP-10	VDD • VOUTA • VOUTB • VOUTC • REFIN • VOUTD • GND • SDA • SCL • A0
DJB	AD9833BRM	AD	gen	f _{OUT} < 12.5 МГц; P ₀ = 30 мВт; V _{DD} = 2.3...5.5 В	MSOP-10	COMP • VDD • CAP/2.5V • DGN • MCLK • SDATA • SCLK • FSYNC • AGND • VOUT
DLA	AD5200BRM-10	AD	Dpot	256 позиций; 10 кОм; SPI	MSOP-10	B • VSS • GND • CS • SDI • CLK • SHDN • VDD • W • A
DLB	AD5200BRM-50	AD	Dpot	256 позиций; 50 кОм; SPI	MSOP-10	B • VSS • GND • CS • SDI • CLK • SHDN • VDD • W • A
DMA	AD5201BRM-10	AD	Dpot	33 позиции; 10 кОм; SPI	MSOP-10	B • VSS • GND • CS • SDI • CLK • SHDN • VDD • W • A
DMB	AD5201BRM-50	AD	Dpot	33 позиции; 50 кОм; SPI	MSOP-10	B • VSS • GND • CS • SDI • CLK • SHDN • VDD • W • A

MSOP-10



US-8

SOT23-8
TSOT23-8MSOP-8
SOP-8

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
DSB	AD5399RM	AD	DAC	2 x 12-разр.; SPI/Microwire; $V_{DD} = 4.5...5.5$ В	MSOP-10	CLK • SDI • DGND • VOUTB • VOUTA • VBZ • AGND • VDD • VTP • CS
DUC	AD5553CRM	AD	DAC	14-разр.; SPI; $V_{DD} = 4.5...5.5$ В	MSOP-8	CLK • SDI • RFB • VREF • IOUT • GND • VDD • CS
DXB	AD5543BRM	AD	DAC	16-разр.; SPI; $V_{DD} = 4.5...5.5$ В	MSOP-8	CLK • SDI • RFB • VREF • IOUT • GND • VDD • CS
DYA	AD5273BRJ1	AD	Dpot	64 позиции; 1 кОм; OTP; I ² C	SOT23-8	W • VDD • GND • SCL • SDA • ADO • B • A
DYB	AD5273BRJ10	AD	Dpot	64 позиции; 10 кОм; OTP; I ² C	SOT23-8	W • VDD • GND • SCL • SDA • ADO • B • A
DYC	AD5273BRJ50	AD	Dpot	64 позиции; 50 кОм; OTP; I ² C	SOT23-8	W • VDD • GND • SCL • SDA • ADO • B • A
DYD	AD5273BRJ100	AD	Dpot	64 позиции; 100 кОм; OTP; I ² C	SOT23-8	W • VDD • GND • SCL • SDA • ADO • B • A
E37	OPA2137EA	TI	dOA	$V_{DD} = 4.5...36/±2.25...±18$ В; $I_S = 600$ мкА; $V_{OS} < ±7$ мВ	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+
E43	OPA2743EA	TI	dOA	R-R; $V_{DD} = 3.5...12/±1.75...±6$ В; $f_{BD} = 7$ МГц; $I_S = 1.7$ мА; $V_{OS} < ±7$ мВ	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+
E53	OPA2353EA	TI	dOA	R-R; $V_{DD} = 2.7...5.5$ В; $f_{BD} = 44$ МГц; $I_S = 9$ мА; $V_{OS} < ±10$ мВ	MSOP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+
G1A	AD8611ARM	AD	cmp	$I_{IN} = 100$ МГц; $P_D = 14$ мВт; $V_{DD} = 3...5$ В	MSOP-8	V+ • +IN • -IN • V- • LATCH • GND • OUT • OUT
G37	OPA337EA	TI	OA	R-R; $V_{DD} = 2.5...5.5$ В; $f_{BD} = 3$ МГц; $I_S = 1.2$ мА; $V_{OS} < ±3.5$ мВ	MSOP-8	n.c. • -IN • +IN • V- • n.c. • OUT • V+ • n.c.
H1B	AD8066ARM	AD	dOA	$f_{BD} = 145$ МГц; $P_D = 150$ мВт; $V_{DD} = 5...24$ В	MSOP-8	VOUT1 • -IN1 • +IN1 • -VS • +IN2 • -IN2 • VOUT2 • +VS
H2B	AD8008ARM	AD	dOA	$f_{BD} = 650$ МГц; $P_D = 120$ мВт; $V_{DD} = 5...12$ В	MSOP-8	VOUT1 • -IN1 • +IN1 • -VS • +IN2 • -IN2 • VOUT2 • +VS
H4A	AD8052ARM	AD	dOA	$f_{BD} = 110$ МГц; $P_D = 60$ мВт; $V_{DD} = 3...12$ В	MSOP-8	OUT1 • -IN1 • +IN1 • -VS • +IN2 • -IN2 • OUT2 • +VS
H5A	AD8056ARM	AD	dOA	$f_{BD} = 300$ МГц; $P_D = 40$ мВт; $V_{DD} = ±4...±6$ В	MSOP-8	OUT1 • -IN1 • +IN1 • -VS • +IN2 • -IN2 • OUT2 • +VS
H5B	AD8028ARM	AD	dOA	$f_{BD} = 185$ МГц; $P_D = 100$ мВт; $V_{DD} = 2.7...12$ В	MSOP-10	VOUTA • -IN A • -IN A • -VS • DIS/SEL A • DIS/SEL B • +IN B • VOUTB • +VS
H5B#	AD8028ARMZ	AD	dOA	$f_{BD} = 185$ МГц; $P_D = 100$ мВт; $V_{DD} = 2.7...12$ В	MSOP-10	VOUTA • -IN A • -IN A • -VS • DIS/SEL A • DIS/SEL B • +IN B • -IN B • VOUTB • +VS
H6A	AD8012ARM	AD	dOA	$f_{BD} = 350$ МГц; $P_D = 12$ мВт; $V_{DD} = ±1.5...±6$ В	MSOP-8	OUT1 • -IN1 • +IN1 • -VS • +IN2 • -IN2 • OUT2 • +VS
H7B	AD8030ARJ	AD	dOA	$f_{BD} = 120$ МГц; $P_D = 18$ мВт; $V_{DD} = 2.7...12$ В	SOT23-8	VOUT1 • -IN1 • +IN1 • -VS • +IN2 • -IN2 • +VOUT2 • +VS
H7C	AD8066ARMZ	AD	dOA	$f_{BD} = 145$ МГц; $P_D = 150$ мВт; $V_{DD} = 5...24$ В	MSOP-8	VOUT1 • -IN1 • +IN1 • -VS • +IN2 • -IN2 • VOUT2 • +VS
H8A	AD8058ARM	AD	dOA	$f_{BD} = 325$ МГц; $P_D = 70$ мВт; $V_{DD} = 3...12$ В	MSOP-8	OUT1 • -IN1 • +IN1 • -VS • +IN2 • -IN2 • OUT2 • +VS
H9A	AD8032ARM	AD	dOA	$f_{BD} = 80$ МГц; $P_D = 16$ мВт; $V_{DD} = 2.7...12$ В	MSOP-8	OUT1 • -IN1 • +IN1 • -VS • +IN2 • -IN2 • OUT2 • +VS
HCA	AD8062ARM	AD	dOA	$f_{BD} = 320$ МГц; $P_D = 75$ мВт; $V_{DD} = 2.7...8$ В	MSOP-8	VOUT1 • -IN1 • +IN1 • -VS • +IN2 • -IN2 • VOUT2 • +VS
HDA	AD8022ARM	AD	dOA	$f_{BD} = 130$ МГц; $P_D = 55$ мВт; $V_{DD} = ±4.5...±13$ В	MSOP-8	OUT1 • -IN1 • +IN1 • -VS • +IN2 • -IN2 • OUT2 • +VS
HDB	AD8022ARMZ	AD	dOA	$f_{BD} = 130$ МГц; $P_D = 55$ мВт; $V_{DD} = ±4.5...±13$ В	MSOP-8	OUT1 • -IN1 • +IN1 • -VS • +IN2 • -IN2 • OUT2 • +VS
HFA	AD8002ARM	AD	dOA	$f_{BD} = 600$ МГц; $P_D = 55$ мВт; $V_{DD} = ±3...±6$ В	MSOP-8	OUT1 • -IN1 • +IN1 • -VS • +IN2 • -IN2 • OUT2 • +VS
HKJ	AD8009ARM	AD	OA	$f_{BD} = 1$ ГГц; $P_D = 100$ мВт; $V_{DD} = ±4...±6$ В	SOT23-8	n.c. • -IN • +IN • -VS • n.c. • OUT • +VS • n.c.
HLA	AD8072JR	AD	dOA	$f_{BD} = 100$ МГц; $P_D = 30$ мВт; $V_{DD} = ±2.5...±6$ В	MSOP-8	OUT1 • -IN1 • +IN1 • -VS • +IN2 • -IN2 • OUT2 • +VS
HMA	AD8132ARM	AD	OA	$f_{BD} = 350$ МГц; $P_D = 70$ мВт; $V_{DD} = ±1.35...±5.5$ В	MSOP-8	-IN • VOCM • V+ • +OUT • -OUT • V- • n.c. • +IN
HMA#	AD8132ARMZ	AD	OA	$f_{BD} = 350$ МГц; $P_D = 70$ мВт; $V_{DD} = ±1.35...±5.5$ В	MSOP-8	-IN • VOCM • V+ • +OUT • -OUT • V- • n.c. • +IN



MSOP-8 **SOT23-8**
SOP-8 **TSOT23-8** **US-8**



MSOP-10

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
HNA	AD8021ARM	AD	OA	$f_{80} = 490$ МГц; $P_0 = 100$ мВт; $V_{DD} = \pm 2.25 \dots \pm 12$ В	MSOP-8	LOG REF • IN • IN • IN • VS • CCOMP • VOUT • VS • DIS
HNA	AD8021ARMZ	AD	OA	$f_{80} = 490$ МГц; $P_0 = 100$ мВт; $V_{DD} = \pm 2.25 \dots \pm 12$ В	MSOP-8	LOG REF • IN • IN • IN • VS • CCOMP • VOUT • VS • DIS
HWA	AD8092ARM	AD	dOA	$f_{80} = 110$ МГц; $P_0 = 60$ мВт; $V_{DD} = 3 \dots 12$ В	MSOP-8	OUT1 • IN1 • IN1 • VS • IN2 • IN2 • OUT • VS
HWA#	AD8092ARMZ	AD	dOA	$f_{80} = 110$ МГц; $P_0 = 60$ мВт; $V_{DD} = 3 \dots 12$ В	MSOP-8	OUT1 • IN1 • IN1 • VS • IN2 • IN2 • OUT • VS
HYA	AD8039ART	AD	dOA	$f_{80} = 350$ МГц; $P_0 = 18$ мВт; $V_{DD} = 3 \dots 12$ В	SOT23-8	VOUT1 • IN1 • IN1 • VS • IN2 • IN2 • VOUT2 • VS
HZA	AD8034ART	AD	dOA	$f_{80} = 80$ МГц; $P_0 = 65$ мВт; $V_{DD} = 5 \dots 24$ В	SOT23-8	VOUT1 • IN1 • IN1 • VS • IN2 • IN2 • VOUT2 • VS
JOA	AD623ARM	AD	IA	$V_{DD} = 3 \dots 12$ В; Gain = 1...1000; $V_{OS} < 500$ мкВ	MSOP-8	RG • IN • IN • VS • REF • OUTPUT • VS • RG
J1A	AD8313ARM	AD	LA	$f_{80} = 0.1 \dots 2.5$ ГГц; DD = 70 дБ; $P_0 = 60$ мВт; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5$ В	MSOP-8	VPOS • INH • INLO • VPOS • PWDN • COMM • VSET • VOUT
J2N	AD8350ARM15	AD	DA	$f_{80} = 1.1$ ГГц; Gain = 15 дБ; $P_0 = 330$ мВт; $V_{DD} = 4 \dots 11$ В	MSOP-8	IN+ • ENBL • VCC • OUT+ • OUT- • GND • GND • IN-
J2P	AD8350ARM20	AD	DA	$f_{80} = 1.1$ ГГц; Gain = 20 дБ; $P_0 = 330$ мВт; $V_{DD} = 4 \dots 11$ В	MSOP-8	IN+ • ENBL • VCC • OUT+ • OUT- • GND • GND • IN-
J3A	AD8361ARM	AD	PD	$f_{80} < 2.5$ ГГц; $P_0 = 12$ мВт; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5$ В	MSOP-8	VPOS • IREF • RFIN • PWDN • COMM • FLTR • VRMS • SREF
J5A	AD8314ARM	AD	LA	$f_{80} = 0.1 \dots 2.7$ ГГц; $P_0 = 30$ мВт; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5$ В	MSOP-8	RFIN • ENBL • VSET • FLTR • COMM • V UP • V DN • VPOS
J6A	AD8310ARM	AD	LA	$f_{80} < 440$ МГц; DD = 95 дБ; $P_0 = 50$ мВт; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5$ В	MSOP-8	INLO • COMM • OFLT • VOUT • VPOS • BFIN • ENBL • INHI
J7A	AD8315ARM	AD	LA	$f_{80} = 0.1 \dots 2.5$ ГГц; $P_0 = 60$ мВт; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5$ В	MSOP-8	RFIN • ENBL • VSET • FLTR • COMM • n.c. • VAPC • VPOS
J8A	AD8316ARM	AD	LA	$f_{80} = 0.1 \dots 2.5$ ГГц; $P_0 = 60$ мВт; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5$ В	MSOP-10	RFIN • ENBL • VSET • FLTR • BSEL • FLT2 • OUT2 • COMM • OUT1 • VPOS
LOC	ADR420ARMZ	AD	vref	XFET@: $V_{IN} = 4 \dots 18$ В; $I_{OUT} = 10$ мА; $V_{OUT} = 2.048$ В	MSOP-8	TP • VIN • n.c. • GND • TRIM • VOUT • n.c. • TP
L7	NLAS324US	ON	asw	2x SPST; $R_{ON} < 55$ Ом; $V_{DD} = 2.7 \dots 6.0$ В	US-8	NC1 • COM1 • IN2 • GND • NC2 • COM2 • IN1 • VCC
L7	NLAS325US	ON	asw	2x SPST; $R_{ON} < 105$ Ом; $V_{DD} = 2.7 \dots 6.0$ В	US-8	NO1 • COM1 • IN2 • GND • NC2 • COM2 • IN1 • VCC
LFA	ADP3335ARM-1.8	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6 \dots 12$ В; $I_{OUT} = 500$ мА; $V_{OUT} = 1.8$ В	MSOP-8	OUT • OUT • OUT • GND • NR • SD • IN • IN
LFC	ADP3335ARM-2.5	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6 \dots 12$ В; $I_{OUT} = 500$ мА; $V_{OUT} = 2.5$ В	MSOP-8	OUT • OUT • OUT • GND • NR • SD • IN • IN
LFD	ADP3335ARM-2.85	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6 \dots 12$ В; $I_{OUT} = 500$ мА; $V_{OUT} = 2.85$ В	MSOP-8	OUT • OUT • OUT • GND • NR • SD • IN • IN
LFE	ADP3335ARM-3.3	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6 \dots 12$ В; $I_{OUT} = 500$ мА; $V_{OUT} = 3.3$ В	MSOP-8	OUT • OUT • OUT • GND • NR • SD • IN • IN
LF	ADP3335ARM-5	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6 \dots 12$ В; $I_{OUT} = 500$ мА; $V_{OUT} = 5$ В	MSOP-8	OUT • OUT • OUT • GND • NR • SD • IN • IN
LHA	ADP3336ARM	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6 \dots 12$ В; $I_{OUT} = 500$ мА; $V_{OUT} = 1.5 \dots 10$ В	MSOP-8	OUT • OUT • OUT • GND • FB • SD • IN • IN
LKA	ADP3333ARM-1.5	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6 \dots 12$ В; $I_{OUT} = 300$ мА; $V_{OUT} = 1.5$ В	MSOP-8	OUT • IN • GND • n.c. • n.c. • n.c. • SD • n.c.
LKB	ADP3333ARM-1.8	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6 \dots 12$ В; $I_{OUT} = 300$ мА; $V_{OUT} = 1.8$ В	MSOP-8	OUT • IN • GND • n.c. • n.c. • n.c. • SD • n.c.
LKC	ADP3333ARM-2.5	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6 \dots 12$ В; $I_{OUT} = 300$ мА; $V_{OUT} = 2.5$ В	MSOP-8	OUT • IN • GND • n.c. • n.c. • n.c. • SD • n.c.
LKD	ADP3333ARM-2.77	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6 \dots 12$ В; $I_{OUT} = 300$ мА; $V_{OUT} = 2.77$ В	MSOP-8	OUT • IN • GND • n.c. • n.c. • n.c. • SD • n.c.
LKE	ADP3333ARM-3	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6 \dots 12$ В; $I_{OUT} = 300$ мА; $V_{OUT} = 3$ В	MSOP-8	OUT • IN • GND • n.c. • n.c. • n.c. • SD • n.c.
LKF	ADP3333ARM-3.15	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6 \dots 12$ В; $I_{OUT} = 300$ мА; $V_{OUT} = 3.15$ В	MSOP-8	OUT • IN • GND • n.c. • n.c. • n.c. • SD • n.c.
LKG	ADP3333ARM-3.3	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6 \dots 12$ В; $I_{OUT} = 300$ мА; $V_{OUT} = 3.3$ В	MSOP-8	OUT • IN • GND • n.c. • n.c. • n.c. • SD • n.c.

MSOP-10



US-8

SOT23-8
TSOT23-8MSOP-8
SOP-8

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•10
LKH	ADP3333ARM-5	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6...12\text{В}$; $I_{OUT} = 300\text{мА}$; $V_{OUT} = 5\text{В}$	MSOP-8	OUT•IN•GND•n.c.•n.c.•n.c.•SD•n.c.
LTOZ	LT1009CMS8	LT	vref	$V_{OUT} = 2.5\text{В}$; ACC < 0.2%; $T_{AMB} = 0...70^\circ\text{C}$	MSOP-8	n.c.•n.c.•n.c.•(-)•ADJ•(+)•n.c.•(+)
M01	ADM101EARM	AD	trans	RS-232; 460 кбит/с; $V_{DD} = 4.5...5.5\text{В}$	MSOP-10	GND•C1•V•TIN•ROUT•RIN• TP•SD•C1+•VCC
M2B	ADM1232ARM	AD	mrc	$V_{FR} = 4.62\text{В}$ (5%)/4.37 В (10%); $V_{DD} = 4.5...5.5\text{В}$; $I_{CC} < 0.5\text{мА}$	MSOP-8	PB•RES•D•TOL•GND•RES•RES• STR•VCC
P0A	ADP3088ARM	AD	reg	$V_{IN} = 2.5...11\text{В}$; $I_{OUT} = 750\text{мА}$; $f_{OSC} = 1\text{МГц}$; $V_{OUT} = 1.25...10.5\text{В}$	MSOP-8	IN•IN•GND•COMP•FB•GND•DRV• SW
P1E	ADP3415LRM	AD	drv	$R_{OUT} < 3\text{Ом}$; $V_{CC} = 5\text{В}$; $I_{CC} < 2\text{мА}$	MSOP-10	IN•SD•DRVLSD•DLY•VCC•DRVL• GND•SW•DRVH•BST
R06	ADR421ARMZ	AD	vref	XFET@; $V_{IN} = 4.5...18\text{В}$; $I_{OUT} = 10\text{мА}$; $V_{OUT} = 2.5\text{В}$	MSOP-8	TP•VIN•n.c.•GND•TRIM•VOUT•n.c.• TP
R0U	ADR423ARMZ	AD	vref	XFET@; $V_{IN} = 5...18\text{В}$; $I_{OUT} = 10\text{мА}$; $V_{OUT} = 3\text{В}$	MSOP-8	TP•VIN•n.c.•GND•TRIM•VOUT•n.c.• TP
R0V	ADR425ARMZ	AD	vref	XFET@; $V_{IN} = 7...18\text{В}$; $I_{OUT} = 10\text{мА}$; $V_{OUT} = 5\text{В}$	MSOP-8	TP•VIN•n.c.•GND•TRIM•VOUT•n.c.• TP
R4A	ADR420ARM	AD	vref	XFET@; $V_{IN} = 4...18\text{В}$; $I_{OUT} = 10\text{мА}$; $V_{OUT} = 2.048\text{В}$	MSOP-8	TP•VIN•n.c.•GND•TRIM•VOUT•n.c.• TP
R5A	ADR421ARM	AD	vref	XFET@; $V_{IN} = 4.5...18\text{В}$; $I_{OUT} = 10\text{мА}$; $V_{OUT} = 2.5\text{В}$	MSOP-8	TP•VIN•n.c.•GND•TRIM•VOUT•n.c.• TP
R6A	ADR423ARM	AD	vref	XFET@; $V_{IN} = 5...18\text{В}$; $I_{OUT} = 10\text{мА}$; $V_{OUT} = 3\text{В}$	MSOP-8	TP•VIN•n.c.•GND•TRIM•VOUT•n.c.~ TP
R7A	ADR425ARM	AD	vref	XFET@; $V_{IN} = 7...18\text{В}$; $I_{OUT} = 10\text{мА}$; $V_{OUT} = 5\text{В}$	MSOP-8	TP•VIN•n.c.~GND•TRIM•VOUT•n.c.~ TP
RHA	ADR430ARM	AD	vref	XFET@; $V_{IN} = 4.1...18\text{В}$; $I_{OUT} = +30/-20\text{мА}$; $V_{OUT} = 2.048\text{В}$	MSOP-8	TP•VIN•n.c.~GND•TRIM•VOUT•n.c.~ TP
RJA	ADR431ARM	AD	vref	XFET@; $V_{IN} = 4.5...18\text{В}$; $I_{OUT} = +30/-20\text{мА}$; $V_{OUT} = 2.5\text{В}$	MSOP-8	TP•VIN•n.c.~GND•TRIM•VOUT•n.c.~ TP
RKA	ADR433ARM	AD	vref	XFET@; $V_{IN} = 5...18\text{В}$; $I_{OUT} = +30/-20\text{мА}$; $V_{OUT} = 3\text{В}$	MSOP-8	TP•VIN•n.c.~GND•TRIM•VOUT•n.c.~ TP
RLA	ADR434ARM	AD	vref	XFET@; $V_{IN} = 6.1...18\text{В}$; $I_{OUT} = +30/-20\text{мА}$; $V_{OUT} = 4.096\text{В}$	MSOP-8	TP•VIN•n.c.~GND•TRIM•VOUT•n.c.~ TP
RMA	ADR435ARM	AD	vref	XFET@; $V_{IN} = 7...18\text{В}$; $I_{OUT} = +30/-20\text{мА}$; $V_{OUT} = 5\text{В}$	MSOP-8	TP•VIN•n.c.~GND•TRIM•VOUT•n.c.~ TP
RNA	ADR439ARM	AD	vref	XFET@; $V_{IN} = 6.5...18\text{В}$; $I_{OUT} = +30/-20\text{мА}$; $V_{OUT} = 4.5\text{В}$	MSOP-8	TP•VIN•n.c.~GND•TRIM•VOUT•n.c.~ TP
S18	ADG602BRMZ	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 5.5\text{Ом}$; $V_{DD} = 2.7...5.5/\pm 2.7...5.5\text{В}$	MSOP-8	D•n.c.~n.c.~VDD•VSS•IN•GND•S
S1B	ADG465BRM	AD	prot	$V_{PROT} < \pm 40\text{В}$; $V_{DD} = \pm 15\text{В}$	MSOP-8	n.c.~VDD•VS1•n.c.~n.c.~VSS•VD1• n.c.
S1G	ADG601BRMZ	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 5.5\text{Ом}$; $V_{DD} = 2.7...5.5/\pm 2.7...5.5\text{В}$	MSOP-8	D•n.c.~n.c.~VDD•VSS•IN•GND•S
S21	ADG620BRMZ	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 8.5\text{Ом}$; $V_{DD} = 2.7...5.5/\pm 2.7...5.5\text{В}$	MSOP-8	D•S1•GND•VDD•n.c.~IN•VSS•S2
S21	ADG620BRMZ	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 8.5\text{Ом}$; $V_{DD} = 2.7...5.5/\pm 2.7...5.5\text{В}$	SOT23-8	D•S1•GND•VDD•n.c.~IN•VSS•S2
S29B	LM3485MM	NS	SPM	$V_{IN} = 4.5...35\text{В}$; $V_{OUT} = 1.242..V_{IN}\text{В}$	MSOP-8	ISENSE•GND•n.c.~FB•ADJ•PWR GND•PGATE•VIN
S3B	ADG701BRM	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 4\text{Ом}$; $V_{DD} = 1.8...5.5\text{В}$	MSOP-8	D•n.c.~n.c.~VDD•n.c.~IN•GND•S
S4B	ADG702BRM	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 4\text{Ом}$; $V_{DD} = 1.8...5.5\text{В}$	MSOP-8	D•n.c.~n.c.~VDD•n.c.~IN•GND•S
S5B	ADG719BRM	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 7\text{Ом}$; $V_{DD} = 1.8...5.5\text{В}$	MSOP-8	D•S1•GND•VDD•n.c.~IN•n.c.~S2
S6B	ADG721BRM	AD	asw	2x SPST; $R_{ON} < 5\text{Ом}$; $V_{DD} = 1.8...5.5\text{В}$	MSOP-8	S1•D1•IN2•GND•S2•D2•IN1•VDD
S7B	ADG722BRM	AD	asw	2x SPST; $R_{ON} < 5\text{Ом}$; $V_{DD} = 1.8...5.5\text{В}$	MSOP-8	S1•D1•IN2•GND•S2•D2•IN1•VDD
S8B	ADG723BRM	AD	asw	2x SPST; $R_{ON} < 5\text{Ом}$; $V_{DD} = 1.8...5.5\text{В}$	MSOP-8	S1•D1•IN2•GND•S2•D2•IN1•VDD
S9B	ADG704BRM	AD	amux	4 kxana; $R_{ON} < 4.5\text{Ом}$; $V_{DD} = 1.8...5.5\text{В}$	MSOP-10	A0•S1•GND•S3•EN•VDD•S4•D• S2•A1
SAB	ADG736BRM	AD	asw	2x SPDT; $R_{ON} < 4.5\text{Ом}$; $V_{DD} = 1.8...5.5\text{В}$	MSOP-10	IN1•S1A•GND•S2A•IN2•D2•S2B• VDD•S1B•D1



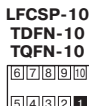
MSOP-8 **SOT23-8**
SOP-8 **TSOT23-8**

US-8



MSOP-10

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
SBB	ADG419BRM	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 70 \text{ Ом}$; $V_{DD} = \pm 15 \text{ В}$; $V_L = 5 \text{ В}$	MSOP-8	D • S1 • GND • VDD • V/L • IN • VSS • S2
SCC	ADG619BRMZ	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 8.5 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 / \pm 2.7 \dots \pm 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • VSS • S2
SCC	ADG619BRTZ	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 8.5 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 / \pm 2.7 \dots \pm 5.5 \text{ В}$	SOT23-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • VSS • S2
SDA	ADG751ARM	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 40 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	n.c. • S • GND • IN • n.c. • n.c. • D • VDD
SDB	ADG751BRM	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 40 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	n.c. • S • GND • IN • n.c. • n.c. • D • VDD
SEB	ADG752BRM	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 20 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	n.c. • S2 • GND • IN • n.c. • S1 • VDD • D
SLB	ADG801BRM	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 0.4 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	D • n.c. • n.c. • VDD • n.c. • IN • GND • S
SMB	ADG802BRM	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 0.4 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	D • n.c. • n.c. • VDD • n.c. • IN • GND • S
SNB	ADG819BRM	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 0.8 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • n.c. • S2
SPB	ADG820BRM	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 0.8 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • n.c. • S2
SOB	ADG821BRM	AD	asw	2xSPST; $R_{ON} < 0.8 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	S1 • D1 • IN2 • GND • S2 • D2 • IN1 • VDD
SRB	ADG822BRM	AD	asw	2xSPST; $R_{ON} < 0.8 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	S1 • D1 • IN2 • GND • S2 • D2 • IN1 • VDD
SSB	ADG823BRM	AD	asw	2xSPST; $R_{ON} < 0.8 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 1.8 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	S1 • D1 • IN2 • GND • S2 • D2 • IN1 • VDD
STB	ADG601BRM	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 5.5 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 / \pm 2.7 \dots \pm 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	D • n.c. • n.c. • VDD • VSS • IN • GND • S
SUB	ADG602BRM	AD	asw	SPST; $R_{ON} < 5.5 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 / \pm 2.7 \dots \pm 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	D • n.c. • n.c. • VDD • VSS • IN • GND • S
SVB	ADG619BRM	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 8.5 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 / \pm 2.7 \dots \pm 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • VSS • S2
SVB	ADG619BRT	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 8.5 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 / \pm 2.7 \dots \pm 5.5 \text{ В}$	SOT23-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • VSS • S2
SWB	ADG620BRM	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 8.5 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 / \pm 2.7 \dots \pm 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • VSS • S2
SWB	ADG620BRT	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 8.5 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 / \pm 2.7 \dots \pm 5.5 \text{ В}$	SOT23-8	D • S1 • GND • VDD • n.c. • IN • VSS • S2
SXB	ADG621BRM	AD	asw	2xSPST; $R_{ON} < 7 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 / \pm 2.7 \dots \pm 5.5 \text{ В}$	MSOP-10	S1 • D1 • IN2 • GND • VSS • n.c. • S2 • D2 • IN1 • VDD
SYB	ADG622BRM	AD	asw	2xSPST; $R_{ON} < 7 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 / \pm 2.7 \dots \pm 5.5 \text{ В}$	MSOP-10	S1 • D1 • IN2 • GND • VSS • n.c. • S2 • D2 • IN1 • VDD
SZB	ADG623BRM	AD	asw	2xSPST; $R_{ON} < 7 \text{ Ом}$; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 / \pm 2.7 \dots \pm 5.5 \text{ В}$	MSOP-10	S1 • D1 • IN2 • GND • VSS • n.c. • S2 • D2 • IN1 • VDD
T13	ADM1032ARMZ-1	AD	dts	2 канала; 108 °C; SMBus; $V_{DD} = 3 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	VDD • D+ • D- • THERM • GND • ALERT • SDATA • SCLK
T1A	ADM1032ARM-1	AD	dts	2 канала; 108 °C; SMBus; $V_{DD} = 3 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	VDD • D+ • D- • THERM • GND • ALERT • SDATA • SCLK
T1C	ADM1032ARMZ-2	AD	dts	2 канала; 85 °C; SMBus; $V_{DD} = 3 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	VDD • D+ • D- • THERM • GND • ALERT • SDATA • SCLK
T1H	ADT7301ARMZ	AD	dts	13-паар.; SPI/QSPI/Microwire; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.25 \text{ В}$	MSOP-8	n.c. • DOUT • CS • SCLK • VDD • DIN • GND • n.c.
T1J	ADM1032ARMZ	AD	dts	2 канала; 85 °C; SMBus; $V_{DD} = 3 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	VDD • D+ • D- • THERM • GND • ALERT • SDATA • SCLK
T2A	ADM1032ARM	AD	dts	2 канала; 85 °C; SMBus; $V_{DD} = 3 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	VDD • D+ • D- • THERM • GND • ALERT • SDATA • SCLK
TOH	AD7414ARMZ	AD	dts	10-паар.; SMBus/I ² C; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	n.c. • SDA • ALERT • SCL • VDD • GND • AS • NC
TOL	AD7414ARMZ	AD	dts	10-паар.; SMBus/I ² C; $V_{DD} = 2.7 \dots 5.5 \text{ В}$	MSOP-8	n.c. • SDA • ALERT • SCL • VDD • GND • AS • NC
V0K	AD7740KRM	AD	VFC	$V_{DD} = 3 \dots 3.6 \text{ В}$; 4/75...5.25 В; синхронный	MSOP-8	CLKOUT • CLKIN • GND • REFIN/OUT • VIN • VDD • FOUT • BUF
V0Y	AD7740YRM	AD	VFC	$V_{DD} = 3 \dots 3.6 \text{ В}$; 4/75...5.25 В; синхронный	MSOP-8	CLKOUT • CLKIN • GND • REFIN/OUT • VIN • VDD • FOUT • BUF
V0Y	AD7740YRT	AD	VFC	$V_{DD} = 3 \dots 3.6 \text{ В}$; 4/75...5.25 В; синхронный	SOT23-8	BUF • FOUT • VDD • VIN • REFIN/OUT • GND • CLKIN • CLKOUT
W1B	ADG3233BRJ	AD	dsw	$t_{PD} < 10.5 \text{ нс}$; $V_{DD} = 1.65 \dots 3.6 \text{ В}$	SOT23-8	VCC1 • A1 • A2 • EN • GND • Y2 • Y1 • VCC2
W1B	ADG3233BRM	AD	dsw	$t_{PD} < 10.5 \text{ нс}$; $V_{DD} = 1.65 \dots 3.6 \text{ В}$	MSOP-8	VCC2 • Y1 • Y2 • GND • EN • A2 • A1 • VCC1



LFCSP, TDFN, TQFN

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•...•16
#DBA	AD5304ACPZ	AD	DAC	4x8-паэр.; SPI/Microwire; $V_{DD}=2.5...5.5B$	LFCSP-10	VDD•VOUTA•VOUTB•VOUTC•REFIN• VOUTD•GND•DIN•SCLK•SYNC
#DBB	AD5304BCPZ	AD	DAC	4x8-паэр.; SPI/Microwire; $V_{DD}=2.5...5.5B$	LFCSP-10	VDD•VOUTA•VOUTB•VOUTC•REFIN• VOUTD•GND•DIN•SCLK•SYNC
#DCA	AD5314ACPZ	AD	DAC	4x10-паэр.; SPI/Microwire; $V_{DD}=2.5...5.5B$	LFCSP-10	VDD•VOUTA•VOUTB•VOUTC•REFIN• VOUTD•GND•DIN•SCLK•SYNC
#DCB	AD5314BCPZ	AD	DAC	4x10-паэр.; SPI/Microwire; $V_{DD}=2.5...5.5B$	LFCSP-10	VDD•VOUTA•VOUTB•VOUTC•REFIN• VOUTD•GND•DIN•SCLK•SYNC
#DDA	AD5324ACPZ	AD	DAC	4x12-паэр.; SPI/Microwire; $V_{DD}=2.5...5.5B$	LFCSP-10	VDD•VOUTA•VOUTB•VOUTC•REFIN• VOUTD•GND•DIN•SCLK•SYNC
#ddb	AD5324BCPZ	AD	DAC	4x12-паэр.; SPI/Microwire; $V_{DD}=2.5...5.5B$	LFCSP-10	VDD•VOUTA•VOUTB•VOUTC•REFIN• VOUTD•GND•DIN•SCLK•SYNC
+AFN	MAX1287ETA	MAX	ADC	2x12-паэр.; SPI/GSPI/Microwire; $V_{DD}=2.7...3.6B$	TDFN-8	VDD•AIN1•AIN2•GND•REF•CNVST• DOUT•SCLK
+AFP	MAX1289ETA	MAX	ADC	12-паэр.; SPI/GSPI/Microwire; $V_{DD}=2.7...3.6B$	TDFN-8	VDD•AIN+•AIN-•GND•REF•CNVST• DOUT•SCLK
+AFR	MAX1286ETA	MAX	ADC	2x12-паэр.; SPI/GSPI/Microwire; $V_{DD}=4.5...5.5B$	TDFN-8	VDD•AIN1•AIN2•GND•REF•CNVST• DOUT•SCLK
+AFT	MAX1288ETA	MAX	ADC	12-паэр.; SPI/GSPI/Microwire; $V_{DD}=4.5...5.5B$	TDFN-8	VDD•AIN+•AIN-•GND•REF•CNVST• DOUT•SCLK
1S1	ZX3CD1S1M832	ZETEX	prnp + shd	$V_{CE0}=12B$; $I_C=4A$; $V_R=40B$; $I_E=1.85A$	MLP-832	B•E•n.c. •A•F2•K•K•C•C•F1
2S1	ZX3CD2S1M832	ZETEX	prnp + shd	$V_{CE0}=20B$; $I_C=3.5A$; $V_R=40B$; $I_E=1.85A$	MLP-832	B•E•n.c. •A•F2•K•K•C•C•F1
3S1	ZX3CD3S1M832	ZETEX	prnp + shd	$V_{CE0}=40B$; $I_C=3A$; $V_R=40B$; $I_E=1.85A$	MLP-832	B•E•n.c. •A•F2•K•K•C•C•F1
91A	ZXTD4591AM832	ZETEX	npr/pnp	$V_{CB0}=40B$; $I_{ON}=2A$; $I_{CP}=1.5A$; $P_D=1.5Bt$	MLP-832	B1•E1•B2•E2•F2•C2•C2•C1•C1•F1
AAAM	MAX1595ETC50	MAX	cpreg	$V_{IN}=1.8...5.5B$; $V_{OUT}=5B$; $I_{OUT}=125mA$	TQFN-12	SHDN•IN•IN•GND•PGND•PGND•CXN• CXN•CXP•OUT•OUT•AOUT
AAAP	MAX1595ETC33	MAX	cpreg	$V_{IN}=1.8...5.5B$; $V_{OUT}=3.3B$; $I_{OUT}=125mA$	TQFN-12	SHDN•IN•IN•GND•PGND•PGND•CXN• CXN•CXP•OUT•OUT•AOUT
AAG	MAX4684ETB	MAX	asw	2xSPDT; $R_{ON}<0.5\Omega$; $V_{DD}=1.8...5.5B$	TQFN-10	V+•NC1•COM1•IN1•NC1•GND•NC2• IN2•COM2•NO2
AAH	MAX4685ETB	MAX	asw	2xSPDT; $R_{ON}<0.8\Omega$; $V_{DD}=1.8...5.5B$	TQFN-10	V+•NC1•COM1•IN1•NC1•GND•NC2• IN2•COM2•NO2
ABW	MAX1605ETT	MAX	vcon	$V_{IN}=2.4...5.5B$; $V_{OUT}=0.8...30B$; $I_{CC}<35mA$	TDFN-6	SHDN•VCC•GND•LX•LIM•FB
ABX	MAX1833ETT30	MAX	vcon	$V_{IN}=1.5...5.5B$; $V_{OUT}=3.3B$; $I_{OUT}<150mA$	TDFN-6	SHDN•BATT•GND•LX•OUT•RST
AGS	MAX8880ETT	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...12B$; $V_{OUT}=1.25...5B$; $I_{OUT}=200mA$	TDFN-6	FB•GND•OUT•IN•SHDN•POK
AJE	MAX1836ETT50	MAX	vcon	$V_{IN}=4.5...24B$; $V_{OUT}=5B$; $I_{OUT}<125mA$	TDFN-6	FB•GND•IN•LX•SHDN•OUT
AJF	MAX1837ETT50	MAX	vcon	$V_{IN}=4.5...24B$; $V_{OUT}=5B$; $I_{OUT}<250mA$	TDFN-6	FB•GND•IN•LX•SHDN•OUT
AJG	MAX1836ETT33	MAX	vcon	$V_{IN}=4.5...24B$; $V_{OUT}=3.3B$; $I_{OUT}<125mA$	TDFN-6	FB•GND•IN•LX•SHDN•OUT
AJH	MAX1837ETT33	MAX	vcon	$V_{IN}=4.5...24B$; $V_{OUT}=3.3B$; $I_{OUT}<250mA$	TDFN-6	FB•GND•IN•LX•SHDN•OUT
AJT	MAX5900NETT	MAX	hscontr	$V_{EE}=-100...-9B$; $I_{CC}<1.3mA$	TDFN-6	VEE•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF
AJU	MAX5900AAETT	MAX	hscontr	$V_{EE}=-100...-9B$; $I_{CC}<1.3mA$; $V_{CB}=200mB$	TDFN-6	VEE•DRAIN•GATE•GND•PGOOD•ON/OFF


TDFN-6

LFCSP-8
TDFN-8

LFCSP-10
TDFN-10
TQFN-10

TQFN-12

LFCSP-16


Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•...•16
AJV	MAX5900ABETT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100...-9B$; $I_{CC} < 1.3mA$; $V_{CB} = 300mB$	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AJW	MAX5900ACETT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100...-9B$; $I_{CC} < 1.3mA$; $V_{CB} = 400mB$	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AJX	MAX5900LAETT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100...-9B$; $I_{CC} < 1.3mA$; $V_{CB} = 200mB$	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AJY	MAX5900LBETT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100...-9B$; $I_{CC} < 1.3mA$; $V_{CB} = 300mB$	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AJZ	MAX5900LCETT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100...-9B$; $I_{CC} < 1.3mA$; $V_{CB} = 400mB$	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKA	MAX5901NNETT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100...-9B$; $I_{CC} < 1.3mA$	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKB	MAX5901AETTT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100...-9B$; $I_{CC} < 1.3mA$; $V_{CB} = 200mB$	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKC	MAX5901ABETT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100...-9B$; $I_{CC} < 1.3mA$; $V_{CB} = 300mB$	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKD	MAX5901ACETT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100...-9B$; $I_{CC} < 1.3mA$; $V_{CB} = 400mB$	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKE	MAX5901LAETT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100...-9B$; $I_{CC} < 1.3mA$; $V_{CB} = 200mB$	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKF	MAX5901LBETT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100...-9B$; $I_{CC} < 1.3mA$; $V_{CB} = 300mB$	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKG	MAX5901LCETT	MAX	hscontr	$V_{EE} = -100...-9B$; $I_{CC} < 1.3mA$; $V_{CB} = 400mB$	TDFN-6	VEE • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKH	MAX5902NNETT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72B$; $I_{CC} < 2mA$	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKI	MAX5902AAEUT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72B$; $I_{CC} < 2mA$; $V_{CB} = 300mB$	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKJ	MAX5902ABETT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72B$; $I_{CC} < 2mA$; $V_{CB} = 400mB$	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKK	MAX5902ACETT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72B$; $I_{CC} < 2mA$; $V_{CB} = 500mB$	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKL	MAX5902LAETT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72B$; $I_{CC} < 2mA$; $V_{CB} = 300mB$	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKM	MAX5902LBETT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72B$; $I_{CC} < 2mA$; $V_{CB} = 400mB$	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKN	MAX5902LCETT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72B$; $I_{CC} < 2mA$; $V_{CB} = 500mB$	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKO	MAX5903NNETT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72B$; $I_{CC} < 2mA$	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKP	MAX5903AAETT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72B$; $I_{CC} < 2mA$; $V_{CB} = 300mB$	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKQ	MAX5903ABETT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72B$; $I_{CC} < 2mA$; $V_{CB} = 400mB$	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKR	MAX5903ACETT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72B$; $I_{CC} < 2mA$; $V_{CB} = 500mB$	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKS	MAX5903LAETT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72B$; $I_{CC} < 2mA$; $V_{CB} = 300mB$	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKT	MAX5903LBETT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72B$; $I_{CC} < 2mA$; $V_{CB} = 400mB$	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKU	MAX5903LCETT	MAX	hscontr	$V_S = +9...+72B$; $I_{CC} < 2mA$; $V_{CB} = 500mB$	TDFN-6	VS • DRAIN • GATE • GND • PGOOD • ON/OFF
AKV	MAX5048AATT	MAX	drv	КМОП-вход; $V_{CC} = 4...12.6B$; $I_{OUT} < 7.6/1.3A$	TDFN-6	V+ • P_OUT • N_OUT • GND • IN • IN+
AKW	MAX5048BATT	MAX	drv	ТТЛ-вход; $V_{CC} = 4...12.6B$; $I_{OUT} < 7.6/1.3A$	TDFN-6	V+ • P_OUT • N_OUT • GND • IN • IN+
BS1	ZX3CDBS1M832	ZETEX	npn + shd	$V_{CE0} = 20B$; $I_C = 4.5A$; $V_E = 40B$; $I_E = 1.85A$	MLP-832	B • E • n.c. • A • F2 • K • K • C • C • F1
C01	ZXMC3AM832	ZETEX	nMOS/p MOS	$V_{DS} = 30B$; $I_{DM} = 2.9A$; $I_{CP} = 2.1A$; $P_{DS(ON)} < 0.180W$; $P_{DS(OFF)} < 0.330W$	MLP-832	S1 • G1 • S2 • G2 • F2 • D2 • D2 • D1 • D1 • F1
D11	ZXTD1M832	ZETEX	pnnp x2	$V_{CE0} = 12B$; $I_C = 4A$; $P_D = 1.5Bt$	MLP-832	B1 • E1 • B2 • E2 • F2 • C2 • C2 • C1 • C1 • F1
D22	ZXTD2M832	ZETEX	pnnp x2	$V_{CE0} = 20B$; $I_C = 3.5A$; $P_D = 1.5Bt$	MLP-832	B1 • E1 • B2 • E2 • F2 • C2 • C2 • C1 • C1 • F1
D33	ZXTD3M832	ZETEX	pnnp x2	$V_{CE0} = 40B$; $I_C = 3A$; $P_D = 1.5Bt$	MLP-832	B1 • E1 • B2 • E2 • F2 • C2 • C2 • C1 • C1 • F1
DA1	ZXTDA1M832	ZETEX	npnp/npnp	$V_{CE0} = 15B$; $V_{CE0} = 12B$; $I_{CN} = 4.5A$; $I_{CP} = 4A$; $P_D = 1.5Bt$	MLP-832	B1 • E1 • B2 • E2 • F2 • C2 • C2 • C1 • C1 • F1
DAA	ZXTDAM832	ZETEX	npnp x2	$V_{CE0} = 15B$; $I_C = 4.5A$; $P_D = 1.5Bt$	MLP-832	B1 • E1 • B2 • E2 • F2 • C2 • C2 • C1 • C1 • F1

LFCSP-16



TQFN-12



LFCSP-10

TDFN-10

TQFN-10



LFCSP-8

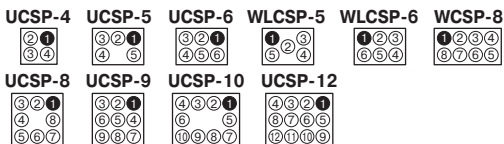
TDFN-8



TDFN-6



Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•5•6•...•16
DB2	ZXTDB2M832	ZETEX	pn/pn/pnp	$V_{CE0N} = 20\text{ В}$; $V_{CE0P} = 20\text{ В}$; $I_{CN} = 4.5\text{ А}$; $I_{CP} = 3.5\text{ А}$; $P_D = 1.5\text{ Вт}$	MLP-832	B1•E1•B2•E2•F2•C2•C2•C1•C1•F1
DBB	ZXTDBM832	ZETEX	pn/pn x2	$V_{CE0} = 20\text{ В}$; $I_C = 4.5\text{ А}$; $P_D = 1.5\text{ Вт}$	MLP-832	B1•E1•B2•E2•F2•C2•C2•C1•C1•F1
DC3	ZXTDC3M832	ZETEX	pn/pn/pnp	$V_{CE0N} = 50\text{ В}$; $V_{CE0P} = 40\text{ В}$; $I_{CN} = 4\text{ А}$; $I_{CP} = 3\text{ А}$; $P_D = 1.5\text{ Вт}$	MLP-832	B1•E1•B2•E2•F2•C2•C2•C1•C1•F1
DCC	ZXTDCM832	ZETEX	pn/pn x2	$V_{CE0} = 50\text{ В}$; $I_C = 4\text{ А}$; $P_D = 1.5\text{ Вт}$	MLP-832	B1•E1•B2•E2•F2•C2•C2•C1•C1•F1
DE4	ZXTDE4M832	ZETEX	pn/pn/pnp	$V_{CE0N} = 80\text{ В}$; $V_{CE0P} = 70\text{ В}$; $I_{CN} = 3.5\text{ А}$; $I_{CP} = 2.5\text{ А}$; $P_D = 1.5\text{ Вт}$	MLP-832	B1•E1•B2•E2•F2•C2•C2•C1•C1•F1
DNA	ZXMN2AM832	ZETEX	nMOS x2	$V_{DS} = 20\text{ В}$; $I_D = 13\text{ А}$; $P_D = 1.5\text{ Вт}$; $R_{DS(on)} < 0.3\text{ Ом}$	MLP-832	S1•G1•S2•G2•F2•D2•D2•D1•D1•F1
DNB	ZXMN3AM832	ZETEX	nMOS x2	$V_{DS} = 30\text{ В}$; $I_D = 13\text{ А}$; $P_D = 1.5\text{ Вт}$; $R_{DS(on)} < 0.18\text{ Ом}$	MLP-832	S1•G1•S2•G2•F2•D2•D2•D1•D1•F1
DPA	ZXMP62M832	ZETEX	pMOS x2	$V_{DS} = 20\text{ В}$; $I_D = 1.3\text{ А}$; $P_D = 1.5\text{ Вт}$; $R_{DS(on)} < 0.9\text{ Ом}$	MLP-832	S1•G1•S2•G2•F2•D2•D2•D1•D1•F1
J5A	AD8314ACP	AD	LA	$f_{BD} = 0.1...2.7\text{ ГГц}$; $P_D = 30\text{ мВт}$; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	LFCSP-8	RFIN•ENBL•VSET•FLTR•COMM•VUP•V DN•VPOS
J7A	AD8315ACP	AD	LA	$f_{BD} = 0.1...2.5\text{ ГГц}$; $P_D = 60\text{ мВт}$; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	LFCSP-8	RFIN•ENBL•VSET•FLTR•COMM•n.c. VAPC•VPOS
J8A	AD8316ACP	AD	LA	$f_{BD} = 0.1...2.5\text{ ГГц}$; $P_D = 60\text{ мВт}$; $V_{DD} = 2.7...5.5\text{ В}$	LFCSP-16	RFIN•ENBL•VSET•FLTR•n.c.•BSEL• FLT2•n.c.•OUT2•COMM•OUT1•VPOS•n. c.•COMM•n.c.•n.c.
LFA	ADP3335ACP-1.8	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6...12\text{ В}$; $I_{OUT} = 500\text{ мА}$; $V_{OUT} = 1.8\text{ В}$	LFCSP-8	OUT•OUT•OUT•GND•NR•SD•IN•IN
LFC	ADP3335ACP-2.5	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6...12\text{ В}$; $I_{OUT} = 500\text{ мА}$; $V_{OUT} = 2.5\text{ В}$	LFCSP-8	OUT•OUT•OUT•GND•NR•SD•IN•IN
LFD	ADP3335ACP-2.85	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6...12\text{ В}$; $I_{OUT} = 500\text{ мА}$; $V_{OUT} = 2.85\text{ В}$	LFCSP-8	OUT•OUT•OUT•GND•NR•SD•IN•IN
LFE	ADP3335ACP-3.3	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6...12\text{ В}$; $I_{OUT} = 500\text{ мА}$; $V_{OUT} = 3.3\text{ В}$	LFCSP-8	OUT•OUT•OUT•GND•NR•SD•IN•IN
LF	ADP3335ACP-5	AD	reg	LDO; $V_{IN} = 2.6...12\text{ В}$; $I_{OUT} = 500\text{ мА}$; $V_{OUT} = 5\text{ В}$	LFCSP-8	OUT•OUT•OUT•GND•NR•SD•IN•IN
MSA	ZXMNS3BM832	ZETEX	nMOS + shd	$V_{DS} = 30\text{ В}$; $I_D = 2\text{ А}$; $V_R = 40\text{ В}$; $I_f = 1.85\text{ А}$	MLP-832	S•G•n.c.•A•F2•K•K•D•D•F1
MSB	ZXMP62M832	ZETEX	pMOS + shd	$V_{DS} = 20\text{ В}$; $I_D = 1.3\text{ А}$; $V_R = 40\text{ В}$; $I_f = 1.85\text{ А}$	MLP-832	S•G•n.c.•A•F2•K•K•D•D•F1



UCSP, WCSP..

Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•...•12
AAA	MAX2240EBL	MAX	amp	$V_{CC}=2.7...5.5$; $f_p=2.4...2.5$ ГГц; $I_{CC}<155$ мА	UCSP-9	D0•D1•BIAS•RFOUT•SHDN•GND1•GND2•VCC•RFIN
AAA	MAX6400BS22	MAX	mrc	$V_{IR}=2.2$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC}<1$ мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
AAB	MAX1820ZEBC	MAX	dcdc	$V_{IN}=2.6...5.5$ В; $V_{OUT}=0.4...3.4$ В; $I_{OUT}=600$ мА	UCSP-10	SKIP•COMP•OUT•REF•GND•PGND•LX•BATT•SHDN•SYNC
AAB	MAX2374EBT	MAX	amp	SiGe; $V_{CC}=2.7...5.5$ В; $f_p=750...1000$ МГц; $I_{CC}<10.5$ мА	UCSP-6	GAIN•LNAin•GND•BIAS•LNAOUT•VCC
AAB	MAX6400BS23	MAX	mrc	$V_{IR}=2.32$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC}<1$ мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
AAC	MAX1819EBL20	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5$ В; $V_{OUT}=2.0/1.25...5.5$ В; $I_{OUT}=500$ мА	UCSP-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AAC	MAX1821EBBC	MAX	dcdc	$V_{IN}=2.6...5.5$ В; $V_{OUT}=1.25...5.5$ В; $I_{OUT}=600$ мА	UCSP-10	SKIP•COMP•FB•REF•GND•PGND•LX•BATT•SHDN•SYNC
AAC	MAX6400BS24	MAX	mrc	$V_{IR}=2.4$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC}<1$ мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
AAD	MAX1819EBL25	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5$ В; $V_{OUT}=2.5/1.25...5.5$ В; $I_{OUT}=500$ мА	UCSP-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AAD	MAX6400BS25	MAX	mrc	$V_{IR}=2.5$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC}<1$ мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
AAE	MAX1819EBL33	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5$ В; $V_{OUT}=3.3/1.25...5.5$ В; $I_{OUT}=500$ мА	UCSP-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AAE	MAX2242EBC	MAX	amp	$V_{CC}=2.7...3.6$ В; $f_p=2.4...2.5$ ГГц; $I_{CC}<335$ мА	UCSP-12	GND•VCC2•GND•VCC1•RF OUT•PD OUT•n.c. •GND•BIAS•SHDN•VCCB•RF IN
AAE	MAX2648EBT	MAX	amp	SiGe; $V_{CC}=2.7...3.6$ В; $f_p=5000+R[1841]C...6000$ МГц; $I_{CC}<18$ мА	UCSP-6	RFIN•GND•GND•VCC•GND•RFOUT
AAE	MAX6400BS26	MAX	mrc	$V_{IR}=2.63$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC}<1$ мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
AAF	MAX1819EBL50	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5$ В; $V_{OUT}=5.0/1.25...5.5$ В; $I_{OUT}=500$ мА	UCSP-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AAF	MAX4684EBC	MAX	asw	2xSPDT; $R_{ON}<0.5$ Ом; $V_{DD}=1.8...5.5$ В	UCSP-10	NC2•IN2•COM2•NO2•GND•V+•NC1•IN1•COM1•NO1
AAF	MAX6400BS27	MAX	mrc	$V_{IR}=2.7$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC}<1$ мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
AAG	MAX1819EBL18	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5$ В; $V_{OUT}=1.8/1.25...5.5$ В; $I_{OUT}=500$ мА	UCSP-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AAG	MAX4685EBC	MAX	asw	2xSPDT; $R_{ON}<0.8$ Ом; $V_{DD}=1.8...5.5$ В	UCSP-10	NC2•IN2•COM2•NO2•GND•V+•NC1•IN1•COM1•NO1
AAG	MAX6400BS28	MAX	mrc	$V_{IR}=2.8$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC}<1$ мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
AAH	MAX1819EBL15	MAX	reg	LDO; $V_{IN}=2.5...5.5$ В; $V_{OUT}=1.5/1.25...5.5$ В; $I_{OUT}=500$ мА	UCSP-6	IN•POK•SHDN•GND•SET•OUT
AAH	MAX2307EBC	MAX	amp	$V_{CC}=2.8...4.2$ В; $f_p=887...925$ МГц; $I_{CC}<38$ мА	UCSP-12	GCC•VCC MIXP•VCC MIXM•GND•L0IN/SHDN•n.c. •GC•RF OUT•GND•IFINP•IFINM•SHDN
AAH	MAX6400BS29	MAX	mrc	$V_{IR}=2.93$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC}<1$ мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
AAI	MAX4686EBT	MAX	asw	SPST; $R_{ON}<3.5$ Ом; $V_{DD}=1.8...5.5$ В	UCSP-6	NO•I.C. •COM•GND•IN•V+
AAI	MAX6400BS30	MAX	mrc	$V_{IR}=3.0$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC}<1$ мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
AAJ	MAX2383BC	MAX	amp	$V_{CC}=2.7...3$ В; $f_p=1920...1980$ МГц; $I_{CC}<44$ мА	UCSP-12	LO+/LO EN•VCC•DROUT•GND•LO-/SHDN•n.c. •GC•DRIN•IFIN•IFIN+•RF OUT•GND
AAJ	MAX4292EBL	MAX	dOA	R-R; $V_{DD}=1.8...5.5/±0.9...±2.75$ В; $f_{BD}=500$ кГц; $V_{DS}<2.5$ мВ	UCSP-8	OUTA•VCC•OUTB•INB•INB+•VEE•INA+•INA-
AAJ	MAX4687EBT	MAX	asw	SPST; $R_{ON}<3.5$ Ом; $V_{DD}=1.8...5.5$ В	UCSP-6	NC•I.C. •COM•GND•IN•V+
AAJ	MAX6400BS31	MAX	mrc	$V_{IR}=3.08$ В; $V_{DD}=1.2...5.5$ В; $I_{CC}<1$ мкА	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
AAK	MAX4688EBT	MAX	asw	SPDT; $R_{ON}<3.5$ Ом; $V_{DD}=1.8...5.5$ В	UCSP-6	NO•COM•NC•GND•IN•V+

WCSP-8

WLCSP-6

WLCSP-5

UCSP-6

UCSP-5

UCSP-4

UCSP-12

UCSP-10

UCSP-9

UCSP-8

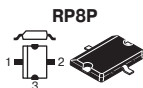

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4•...•12
AAK	MAX6410BS33	MAX	vd	$V_{TR} = 3.30\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAL	MAX1820XEBC	MAX	ddcdc	$V_{IN} = 2.6...5.5\text{ В}; V_{OUT} = 0.4...3.4\text{ В}; f_{CLK} = 19.8\text{ МГц}; I_{OUT} = 600\text{ мА}$	UCSP-10	SKIP•COMP•OUT•REF•GND•PGND•LX•BATT•SHDN•SYNC
AAL	MAX4696EBT	MAX	asw	SPST; $R_{ON} < 40\text{ Ом}; V_{DD} = 2.0...5.5\text{ В}$	UCSP-6	NO•COM•COM•GND•IN•V+
AAL	MAX6410BS34	MAX	vd	$V_{TR} = 3.40\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAM	MAX1820XEBC	MAX	ddcdc	$V_{IN} = 2.6...5.5\text{ В}; V_{OUT} = 0.4...3.4\text{ В}; f_{CLK} = 13\text{ МГц}; I_{OUT} = 600\text{ мА}$	UCSP-10	SKIP•COMP•OUT•REF•GND•PGND•LX•BATT•SHDN•SYNC
AAM	MAX4697EBT	MAX	asw	SPST; $R_{ON} < 40\text{ Ом}; V_{DD} = 2.0...5.5\text{ В}$	UCSP-6	NC•COM•COM•GND•IN•V+
AAM	MAX6410BS35	MAX	vd	$V_{TR} = 3.30\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAN	MAX4698EBT	MAX	asw	SPDT; $R_{ON} < 40\text{ Ом}; V_{DD} = 2.0...5.5\text{ В}$	UCSP-6	NO•COM•NC•GND•IN•V+
AAN	MAX6410BS36	MAX	vd	$V_{TR} = 3.60\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAO	MAX6410BS37	MAX	vd	$V_{TR} = 3.70\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAP	MAX6410BS38	MAX	vd	$V_{TR} = 3.80\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAQ	MAX6410BS39	MAX	vd	$V_{TR} = 3.90\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAR	MAX6410BS40	MAX	vd	$V_{TR} = 4.00\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AA8	MAX6410BS41	MAX	vd	$V_{TR} = 4.10\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAT	MAX6410BS42	MAX	vd	$V_{TR} = 4.20\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAU	MAX6410BS43	MAX	vd	$V_{TR} = 4.30\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAV	MAX1821XEBC	MAX	ddcdc	$V_{IN} = 2.6...5.5\text{ В}; V_{OUT} = 1.25...5.5\text{ В}; f_{CLK} = 13\text{ МГц}; I_{OUT} = 600\text{ мА}$	UCSP-10	SKIP•COMP•FB•REF•GND•PGND•LX•BATT•SHDN•SYNC
AAV	MAX6410BS44	MAX	vd	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAW	MAX4323EBT	MAX	OA	R-R; $V_{DD} = 2.4...6.5/1.2...3.25\text{ В}; f_{BD} = 5\text{ МГц}; V_{OS} < 3.5\text{ мВ}$	UCSP-6	VEE•OUT•VCC•SHDN•IN•IN+
AAW	MAX6410BS45	MAX	vd	$V_{TR} = 4.50\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAX	MAX6410BS46	MAX	vd	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAZ	MAX6411BS33	MAX	vd	$V_{TR} = 3.30\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAZ	MAX985EBT	MAX	cmp	R-R; $V_{OS} < \pm 7\text{ мВ}; V_{CC} = 2.5...5.5\text{ В}; I_{CC} < 24\text{ мкА}$	UCSP-6	VEE•OUT•VCC•n. c. •IN•IN+
AAZ	MAX6411BS34	MAX	vd	$V_{TR} = 3.40\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
AAZ	MAX90399EBT	MAX	cmp + wref	R-R; $V_{OS} < \pm 7\text{ мВ}; V_{CC} = 2.5...5.5\text{ В}; V_{REF} = 1.230\text{ В}; I_{CC} < 72\text{ мкА}$	UCSP-6	VEE•OUT•VCC•REF•IN•IN+
ABA	MAX6411BS35	MAX	vd	$V_{TR} = 3.50\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABA	MAX6411BS36	MAX	vd	$V_{TR} = 3.60\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABC	MAX6411BS37	MAX	vd	$V_{TR} = 3.70\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABD	MAX6411BS38	MAX	vd	$V_{TR} = 3.80\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABE	MAX6411BS39	MAX	vd	$V_{TR} = 3.90\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABF	MAX6411BS40	MAX	vd	$V_{TR} = 4.00\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABG	MAX6411BS41	MAX	vd	$V_{TR} = 4.10\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABH	MAX6411BS42	MAX	vd	$V_{TR} = 4.20\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABI	MAX6411BS43	MAX	vd	$V_{TR} = 4.30\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABJ	MAX6411BS44	MAX	vd	$V_{TR} = 4.38\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABK	MAX6411BS45	MAX	vd	$V_{TR} = 4.50\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABL	MAX6411BS46	MAX	vd	$V_{TR} = 4.63\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1.75\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•OUT
ABM	MAX6401BS22	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.2\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ABN	MAX6401BS23	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.32\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ABO	MAX6401BS24	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.4\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET
ABP	MAX6401BS25	MAX	mrc	$V_{TR} = 2.5\text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5\text{ В}; I_{CC} < 1\text{ мкА}$	UCSP-4	GND•VCC•MR•RESET

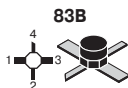
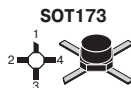


UCSP-4 UCSP-5 UCSP-6 WLCSP-5 WLCSP-6 WCSP-8



Код	Типономинал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1*2*3*4*...*12
AEX	MAX6408BS29	MAX	vd	$V_{TR} = 2.93 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEY	MAX6408BS30	MAX	vd	$V_{TR} = 3.00 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AEZ	MAX6408BS31	MAX	vd	$V_{TR} = 3.08 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFA	MAX6409BS33	MAX	vd	$V_{TR} = 3.30 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFB	MAX6409BS34	MAX	vd	$V_{TR} = 3.40 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFC	MAX6409BS35	MAX	vd	$V_{TR} = 3.50 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFD	MAX6409BS36	MAX	vd	$V_{TR} = 3.60 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFE	MAX6409BS37	MAX	vd	$V_{TR} = 3.70 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFF	MAX6409BS38	MAX	vd	$V_{TR} = 3.80 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFG	MAX6409BS39	MAX	vd	$V_{TR} = 3.90 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFH	MAX6409BS40	MAX	vd	$V_{TR} = 4.00 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFI	MAX6409BS41	MAX	vd	$V_{TR} = 4.10 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFJ	MAX6409BS42	MAX	vd	$V_{TR} = 4.20 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFK	MAX6409BS43	MAX	vd	$V_{TR} = 4.30 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFL	MAX6409BS44	MAX	vd	$V_{TR} = 4.38 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFM	MAX6409BS45	MAX	vd	$V_{TR} = 4.50 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
AFN	MAX6409BS46	MAX	vd	$V_{TR} = 4.63 \text{ В}; V_{DD} = 1.2...5.5 \text{ В}; I_{CC} < 1.75 \text{ мкА}$	UCSP-4	GND • VCC • MR • OUT
B3A	AD8605ACB	AD	0A	$f_{BD} = 10 \text{ МГц}; P_D = 7 \text{ мВт}; V_{DD} = 2.7...5.5 \text{ В}$	WLCSP-5	OUT • V- • IN • -IN • V+
CCS	OPA2347YED	TI	dOA	R-R; $V_{DD} = 2.3...5.5 \text{ В}; f_{BD} = 350 \text{ кГц}; I_S = 80 \text{ мкА}; V_{OS} < 7 \text{ мВ}$	WCSP-8	OUT A • -IN A • +IN A • V- • +IN B • -IN B • OUT B • V+
SNB	ADG819BCB	AD	asw	SPDT; $R_{ON} < 0.8 \text{ Ом}; V_{DD} = 1.8...5.5 \text{ В}$	WLCSP-6	S2 • D • S1 • GND • VDD • IN

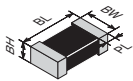

RP8P

Cerec-X

83B

SOT173

SOT173...

Код	Типоминал	Б	Ф	Особенности	Корпус	Ц: 1•2•3•4
57	BFG57	SIEM	nnp	$V_{CBO} = 25 \text{ В}; I_C = 35 \text{ мА}; P_D = 450 \text{ мВт}$	SOT-173	В•Е•С•Е
58	BFG58	SIEM	nnp	$V_{CBO} = 16 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 450 \text{ мВт}$	SOT-173	В•Е•С•Е
70	BFG70	SIEM	nnp	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 35 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T = 5 \text{ ГГц}$	SOT-173	В•Е•С•Е
71	BFG71	SIEM	nnp	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 40; f_T = 5.2 \text{ ГГц}$	SOT-173	В•Е•С•Е
72	BFG72	SIEM	nnp	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} > 40; f_T = 5.1 \text{ ГГц}$	SOT-173	В•Е•С•Е
74	BFG74	SIEM	nnp	$V_{CBO} = 25 \text{ В}; I_C = 35 \text{ мА}; P_D = 300 \text{ мВт}; h_{21} > 50; f_T = 6 \text{ ГГц}$	SOT-173	В•Е•С•Е
75	BFG75	SIEM	npnp	$V_{CBO} = 15 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} > 20; f_T = 5 \text{ ГГц}$	SOT-173	В•Е•С•Е
76	BFG76	SIEM	npnp	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 20; f_T = 5 \text{ ГГц}$	SOT-173	В•Е•С•Е
77	BFG77	SIEM	nnp	$V_{CBO} = 25 \text{ В}; I_C = 20 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; f_T = 2 \text{ ГГц}$	SOT-173	В•Е•С•Е
0	2SC3603	NEC	nnp	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 580 \text{ мВт}; h_{21} = 50 \dots 300; f_T = 7 \text{ ГГц}$	SOT-173	В•Е•С•Е
1	2SC3587	NEC	nnp	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 35 \text{ мА}; P_D = 580 \text{ мВт}; h_{21} = 50 \dots 250; f_T = 10 \text{ ГГц}$	SOT-173	В•Е•С•Е
32	BAT32	INF	shd	$V_R < 6.5 \text{ В}; I_F < 50 \text{ мА}; V_F (I_F = 10 \text{ мА}) < 0.6 \text{ В}; C_D = 0.24 \text{ нФ}$	Cerec-X	А•К
674	NE67483B	NEC	nMESFET	$\text{GaAs}; V_{DS} = 5 \text{ В}; I_D = 120 \text{ мА}; P_D = 270 \text{ мВт}; g_f < 100 \text{ мСм}$	83B	С•D•S•G
73S	BFG73S	SIEM	nnp	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} > 30; f_T = 5.3 \text{ ГГц}$	SOT-173	В•Е•С•Е
C1	BFG51C	PHIL	npnp	$V_{CBO} = 15 \text{ В}; I_C = 30 \text{ мА}; P_D = 250 \text{ мВт}; h_{21} > 20; f_T > 5 \text{ ГГц}$	SOT-173	В•Е•С•Е
C2	BFG32C	PHIL	npnp	$V_{CBO} = 15 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} > 20; f_T > 4.5 \text{ ГГц}$	SOT-173	В•Е•С•Е
C3	BFG23C	PHIL	npnp	$V_{CBO} = 15 \text{ В}; I_C = 50 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}; h_{21} > 20; f_T > 5 \text{ ГГц}$	SOT-173	В•Е•С•Е
IX	2SK3390	REN	nMOS	$V_{DS} = 17 \text{ В}; I_D = 1 \text{ А}; P_D = 20 \text{ Вт}$	RP8P	G•S•D
P0	BFP90A	PHIL	nnp	$V_{CBO} = 15 \text{ В}; I_C = 80 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}$	SOT-173	В•Е•С•Е
P1	BFP91A	PHIL	nnp	$V_{CBO} = 15 \text{ В}; I_C = 80 \text{ мА}; P_D = 350 \text{ мВт}$	SOT-173	В•Е•С•Е
P6	BFP96	PHIL	nnp	$V_{CBO} = 20 \text{ В}; I_C = 100 \text{ мА}; P_D = 500 \text{ мВт}; h_{21} > 25; f_T > 5 \text{ ГГц}$	SOT-173	В•Е•С•Е

РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

	1:1		BL	BW	BH	PL
	Резисторы <i>стр. 16</i> Конденсаторы <i>стр. 17</i> Индуктивности Термисторы Варисторы		0402 (1005)	1	0.5	0.35...0.55
		0603 (1608)	1.6	0.8	0.45...0.95	0.3
		0805 (2012)	2	1.2	0.4...1.6	0.5
		1206 (3216)	3.2	1.6	0.4...1.75	0.5
		1210 (3225)	3.2	2.5	0.55...1.9	0.5
		1218 (3245)	3.2	4.5	0.55...1.9	0.5
		1806 (4516)	4.5	1.6	1.6	0.5
		1808 (4520)	4.5	2	2	0.5
		1812 (4532)	4.5	3.2	0.6...2.3	0.5
		2010 (5025)	5	2.5	0.55	0.5
		2220 (5750)	5.7	5	1.7	0.5
		2225 (5763)	5.7	6.3	2	0.5
		2512 (6432)	6.4	3.2	2	0.5
		2824 (7161)	7.1	6.1	3.9	0.5
		3225 (8063)	8	6.3	3.2	0.5
		4030	10.2	7.6	3.9	0.5
		4032	10.2	8	3.2	0.5
		5040	12.7	10.2	4.8	0.5
	6054	15.2	13.7	4.8	0.5	

Размеры корпусов для поверхностного монтажа

	1:1	Тип	BL	BW	BH	PB	PW	PH	SB	SL	SW
	•	SOD623	1.0	0.6	0.52	1.4	0.2	0.12			
	•	SOD723	1.0	0.6	0.52	1.4	0.29	0.1			
	•	SOD523, SC79	1.2	0.8	0.6	1.6	0.3	0.14			
	•	SCD80	1.3	0.8	0.7	1.7	0.3	0.13	1.8	0.35	0.35
	1:1	Тип	BL	BW	BH	PB	PW	PH	SB	SL	SW
	•	ESC	1.2	0.8	0.6	1.6	0.3				
	•	SSC	1.3	0.8	0.8	2.1	0.3				
	•	SOD323, SC76	1.7	1.25	0.9	2.5	0.3	0.15	3.3	0.8	0.6
	•	SOD123	2.7	1.55	1.35	3.2	0.6	0.15	4.19	0.91	1.22
	•	DO215AC	4.3	2.6	2.4	6.1	1.4				
	•	DO215AA	4.3	3.6	2.3	6.2	2.0	0.25			
	1:1	Тип	BL	BW	BH	PB	PW	PH	SB	SL	SW
	•	2012 (0805)		1.2	1.2	1.1			2		
	•	3216L 3216 (1206)		1.6	1.6	1.2			3.2		
	•	3528L 3528		2.8	1.2 1.9	2.2			3.5		
	•	DO214AC SMA	4.4	2.6	2.15	1.5	0.15	5.2	5.5	1.7	2
	•	DO214BA		2.6	2.95	1.3			5.25		
	•	DO214AA SMB	4.4	3.6	2.2	2	0.2	5.4	6.1	2	2.5
	•	SOD6		3.8	2.5	2.2			5.5		
	•	5832		3.2	1.5	2.2			5.8		
	•	5845		4.5	3.1	2.2			5.8		
	•	6032		3.2	2.5	2.2			6		
	•	7343 7343H		4.3	2.8 4.3	2.4			7.3		
	•	SOD15		5	2.8	3			7.8		
•	DO214AB, SMC	6.8	5.8	2.3	3	0.2	7.9	8.5	2.2	3.5	

Конденсаторы
стр. 17

Индуктивности
стр. 18

Термисторы
Варисторы

Диоды
Стабилитроны
стр. 35 (DO214)
стр. 63 (DO215)
стр. 82 (DO219)

Размеры корпусов для поверхностного монтажа

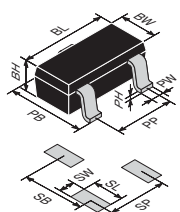





		 Метка 1 Катод 2 Анод Вид сверху		SOD110	Стабилитроны <i>стр. 35</i>
--	--	-------------------------------------------	--	---------------	--------------------------------

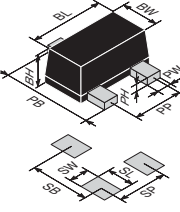





		 Катод 1 Анод 2		DO216AA Powermite	Стабилитроны <i>стр. 63</i>
--	--	-----------------------	--	--------------------------	--------------------------------

 Резисторы <i>стр. 8</i> Конденсаторы Диоды Стабилитроны	1:1	Тип корпуса	BL	BD	PL	PH	Источник
		ERD03LL	1.6	1	0.2	0.05	PANASONIC
		ERO21L	2	1.25	0.3	0.07	PANASONIC
		DO213AC	3.45	1.4	0.42	-	JEDEC
		SOD80, miniMELF	3.5	1.6	0.3	0.075	PHILIPS
		DO213AA, SOD80	3.5	1.65	0.48	0.03	JEDEC
		SOD80C	3.6	1.52	0.3	0.075	PHILIPS
		SOD87	3.5	2.05	0.3	0.075	PHILIPS
		MELF	5	2.5	0.5	0.1	CENTS
	DO213AB, MELF	5	2.52	0.48	0.03	JEDEC	
	ERSM	5.9	2.2	0.6	0.15	PANASONIC	

				TSLP-2	Диоды Варикапы Транзисторы <i>стр. 88</i>
				TSLP-3	
				TSLP-4	
				μDFN-6	

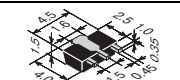
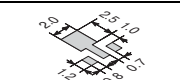

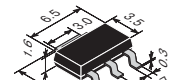
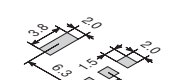




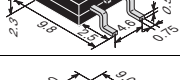


Размеры корпусов для поверхностного монтажа

	1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB
		1	SOT523	1	1.6	0.8	0.75	0.22	0.12	1.6		
	1	SOT416, SC75A	1	1.6	0.8	0.75	0.2	0.15	1.6	0.4	0.65	1.15
	1.3	SOT323, SC70	2	1.25	0.9	0.32	0.13	2.1	0.45	0.9	1.5	
	1.9	SOT346, SC59	2.9	1.5	1	0.4	0.18	2.8				
	1.9	SOT23, SOD23	2.9	1.5	1.1	0.42	0.13	2.8	0.55	1.05	1.95	

	1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB
		0.8	TSFP-3, VESM	1.2	0.8	0.53	0.2	0.15	1.2			
	0.8	VMT3, VMD3	1.2	0.8	0.5	0.22*	0.13	1.2				
	0.9	SC81, MFPK	1.4	0.8	0.57	0.22	0.13	1.2	0.35	0.5	0.75	
	0.9	TESM	1.4	0.8	0.59	0.22	0.14	1.2				
	1	SOT490, SC89	1.6	0.85	0.7	0.28	0.15	1.6				

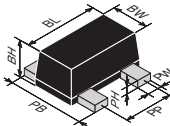


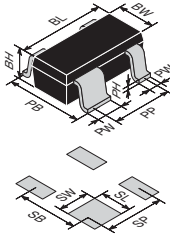







Диоды, Стабилитроны
Транзисторы, Датчики
Стабилизаторы
Схемы сброса
стр. 90

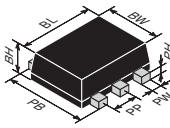

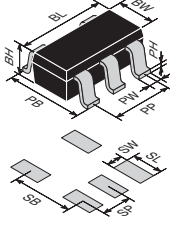



* Для вывода 3: PW = 0.32

		 Вид сверху	SOT89, SC62
			SOT223, TO261AA
			TO252, DPAK
			TO263, D2PAK

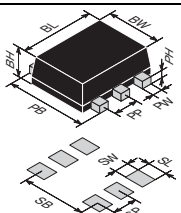
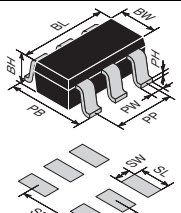
Диоды
Стабилитроны
Транзисторы
Стабилизаторы
Мониторы
Схемы сброса
АЦП
стр. 229

Размеры корпусов для поверхностного монтажа

	1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB
			TSFP-4	1	1.4	0.8	0.55	0.2	0.15	1.2		
		MFPАK-4	1.3*	2	1.25	0.59	0.3*	0.11	2.05			
* Для вывода 2: PW = 0.4, PP = 1.25												
	1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB
		SC82, USQ	1.3	2	1.25	0.95	0.2	0.15	2.1			
		SOT343, SC82A	1.3 ¹⁾	2	1.25	1	0.3 ¹⁾	0.12	2	0.5 ¹⁾	0.55	1.85
		SOT343R	1.3 ¹⁾	2	1.25	1	0.3 ¹⁾	0.12	2	0.5 ¹⁾	0.55	1.85
		MW-4	1.3 ²⁾	2.9	1.3	1	0.4 ²⁾	0.12	2.6			
		SOT143, TO253	1.9	2.9	1.3	1	0.4 ³⁾	0.1	2.5	0.5 ³⁾	0.6	1.9
		SOT143R	1.9	2.9	1.3	1	0.4 ³⁾	0.1	2.5	0.5 ³⁾	0.6	1.9
	SC61, MPAK-4	1.9	2.9	1.5	1.1	0.4 ⁴⁾	0.16	2.9 ⁵⁾				
Диоды Варикапы Транзисторы ИС стр. 244	¹⁾ Для вывода 1: PW = 0.6, SW = 0.7, PP = 1.15 ²⁾ Для выводов 1 и 4: PW = 0.7, PP = 1.15 ³⁾ Для вывода 1: PW = 0.8, SW = 0.9 ⁴⁾ Для вывода 4: PW = 0.6 ⁵⁾ Выводы имеют разную длину: 0.55 для выводов 1, 2 и 0.85 для выводов 3, 4											

	1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB
			SOT553, EMT5	0.5	1.6	1.2	0.55	0.2	0.12	1.6		
	1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB
		SOT353, SC88A	0.65	2	1.25	0.9	0.22	0.15	2.1	0.5	0.55	1.85
		TSOT23-5	0.95	2.9	1.6	0.87	0.4	0.14	2.8			
		SOT23-5	0.95	2.9	1.6	1.15	0.4	0.15	2.8	0.65	1.06	2.2
Диоды Транзисторы ИС стр. 261												

Размеры корпусов для поверхностного монтажа

	1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB	
		■	fs6	0.35	1	0.8	0.48	0.15	0.1	1			
	■	M16, 1208	0.4	1.2	0.8	0.5	0.15	0.125	1				
	■	USM-6	0.48	1.5	1.1	0.55	0.2	0.11	1.5				
	■	SOT666	0.5	1.6	1.2	0.55	0.2	0.12	1.6	0.4	0.5	1.7	
	■	SOT563, EMT6	0.5	1.6	1.2	0.55	0.22	0.12	1.6				
	■	SON-6	0.5	1.6	2.6	0.8	0.2	0.13	3				
 <p style="text-align: center;">Диоды, Транзисторы, ИС стр. 285</p>	1:1	Тип корпуса	PP	BL	BW	BH	PW	PH	PB	SW	SL	SB	
		■	TSOT363	0.65	2	1.25	0.6	0.22	0.13	2.1			
		■	SOT363, SC88	0.65	2	1.25	0.9	0.22	0.15	2.1	0.3	0.7	1.6
		■	MW-6	0.95	2.9	1.3	1	0.3*	0.12	2.6			
		■	SOT457, SC74	0.95	2.9	1.6	1	0.35	0.15	2.5	0.5	0.5	2.4
		■	TSOT23-6	0.95	2.9	1.6	0.88	0.4	0.18	2.75			
	■	SOT23-6	0.95	2.9	1.6	1.15	0.4	0.15	2.8	0.65	1.06	2.2	
			* Для вывода 5: PW = 0.6										

			US-8 VSSOP-8 SOT765	Транзисторы ИС стр. 325
			SOT23-8	
			MSOP-8	
			MSOP-10	
			SOP-8	

Размеры корпусов для поверхностного монтажа

	 Вид снизу		MLP832-8	Транзисторы ИС стр. 345
	 Вид снизу		LFCSP-8	
	 Вид снизу		LFCSP-10	
	 Вид снизу		TDFN-6	
	 Вид снизу		TDFN-8	
	 Вид снизу		TDFN-10, TQFN-10	
	 Вид снизу		TQFN-12	
	 Вид снизу		UCSP-4 2 × 2	ИС стр. 348
	 Вид снизу Вид снизу		UCSP-5 UCSP-6 3 × 2	
	 Вид снизу Вид снизу		UCSP-8 UCSP-9 3 × 3	

Размеры корпусов для поверхностного монтажа

	<p>Вид снизу</p>	<p>Вид снизу</p>	 UCSP-10 UCSP-12 4 × 3	ИС стр. 348
	<p>Вид снизу</p>	 WLCSP-5 2 × 1 × 2		
	<p>Вид снизу</p>	 WLCSP-6 2 × 3		
	<p>Вид снизу</p>	 WCSP-8 4 × 2		
			CerecX	Диоды Транзисторы стр. 353
			83B	
			SOT173	
			RP8P	

СПИСОК ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Сокращение	Полное название фирмы
8X8	8x8, Inc.
ACAP	Acapella, Ltd.
ACC	ACC Microelectronics Corp.
ACCUL	Acculin, Inc.
ACTEL	Actel Corporation
AD	Analog Devices
ADAP	Adaptec
AEROF	Aeroflex Circuit Technology
AGI	Agilent
AHA	Advanced Hardware Architectures, Inc.
AIT	AlTech International
AKM	AKM Semiconductor, Inc.
ALD	Advanced Linear Devices
ALLEG	Allegro Micro Systems, Inc.
ALLIA	Alliance Semiconductor
ALPHA	Alpha Semiconductor
ALT	AverLogic Technologies, Inc.
ALTER	Altera Corporation
AMC	Accutec Microcircuit Corporation
AMCC	AMCC (Applied Micro Circuits Corp)
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.
AMI	American Microsystems, Inc.
AMS	Applied Microsystems Corporation
AMSI	Austria Mikro Systeme International, Inc.
ANAD	Anadigics, Inc.
ANALO	Analogic Corporation
APEX	Apex Microtechnology Corporation
APTEK	Aptek Williams, Inc.
APTOS	Aptos Semiconductor Corporation
ARRAY	Array Microsystems
AS	Analog Systems
ASHL	Ashling Microsystems Ltd
ASPEC	Aspec Technology, Inc.
ASTEC	Astec Semiconductor
ATMEL	ATMEL Corporation
AUK	AUK Semiconductor
AUST	Austin Semiconductor, Inc.
AVG	AVG Semiconductors
AVX	AVX KYOCERA
BB	BurrBrown Corporation
BEL	Bel Fuse Incorporated
BENCH	Benchmark Microelectronics
BOUR	BOURNS
BROOK	Brooktree Corporation
BUTT	ButterflyDSP, Inc.
C&T	Chips and Technologies, Incorporated
CALOG	Calogic Corporation
CATAL	Catalyst Semiconductor

Сокращение	Полное название фирмы
CCD	Cologne Chip Designs
CDIL	CDIL
CEC	Chip Express Corporation
CENTO	Centon Electronics, Inc.
CENTU	Century Microelectronics, Inc.
CERM	Cermetek Microelectronics, Inc.
CHERR	Cherry Semiconductor Corporation
CHRON	Chrontel
CL	Cirrus Logic, Inc.
CMDC	California Micro Devices Corporation
CML	Consumer Microcircuits Limited
CNTRL	Central Semiconductor
COLOR	Colorado Microcircuits
COMC	Comcore Semiconductor
COML	Comlinear Corporation
CONV	Conversion Devices, Inc.
CPC	CP Clare Corporation
CPS	Crosspoint Solutions, Inc.
CROSS	Crosslink Semiconductor, Inc.
CRYST	Crystal
CSC	Central Semiconductor Corp
CSI	Central Semiconductor, Inc.
CTC	CTC
CYBER	Cybernetic Micro Systems
CYPR	Cypress Semiconductor Corp.
CYRIX	Cyrix Corporation
CYS	CYTech Electronic Corporation
DALL	Dallas Semiconductor
DALSA	Dalsa Incorporated
DATEL	Datel, Inc.
DDD	Data Delay Devices, Inc.
DENSE	DensePac Microsystems, Inc.
DIGIT	Digital Semiconductor
DIODS	Diodes Incorporated
DION	Dionics Inc.
DIOT	Diotec Semiconductor
DSPG	DSP Group, Inc.
EDGE	Edge Technology, Inc.
EDI	Electronic Designs Inc.
EG&GI	EG&G IC Sensors
EG&GR	EG&G Reticon Corporation
ELANT	Elantec, Inc.
ELET	Eletech Electronics
ELMOS	Elmos Elektronik in MOSTechnologie GmbH
ELNA	ELNA
EMBED	Embedded Support Tools Corp.
EMM	EM Microelectronics
EMS	Enhanced Memory Systems, Inc.

Список фирм-производителей

Сокращение	Полное название фирмы
EMUL	Emulation Technology, Inc.
ENABL	Enable Semiconductor, Inc.
EPSON	Epson America Inc.
ERIC	Ericsson Components
ESC	ESC Electronics Corporation
ESS	ESS Technology, Inc.
ETC	Electronic Technology Corporation
EUROM	Eurom Ltd.
EXAR	Exar Corporation
EXEL	EXEL Microelectronics, Inc.
EXPO	Exponential Technology, Inc.
FAIR	Fairchild Semiconductor
FUJIT	Fujitsu Microelectronics, Inc.
GALIL	Galileo Technology
GENES	Genesis Microchip Inc.
GENN	Gennum Corporation
GETE	GET Engineering Corp.
GLINK	GLink Technology Corporation
GOAL	Goal Electronics Inc.
GREEN	Greenwich Instruments USA
GS	General Semiconductor
GSI	GSI Technology
HARR	Harris Corporation
HIFN	Hifn
HIT	Hitachi Semiconductor (America), Inc.
HOLT	Holt Integrated Circuits, Inc.
HOLTE	Holtek Microelectronics Inc.
HONEY	Honeywell Solid State Electronics Ctr.
HP	HewlettPackard Logic Systems Division
HUAL	Hualon Microelectronics Corp
HUGH	Hughes Aircraft Co.
HUNT	Huntsville Microsystems, Inc.
HYU	Hyundai Electronics America
IBM	IBM Corporation
ICH	IC Haus
ICS	Integrated Circuit Systems, Inc.
ICT	ICT Inc
ICW	IC Works, Inc.
IDC	IDC Semiconductors
IDEAL	Ideal Semiconductor
IDT	Integrated Device Technology, Inc.
ILC	ILC Data Device Corp.
ILS	Integrated Logic Systems Inc.
IMI	International Microcircuits, Inc.
IMP	IMP, Inc.
IMPAL	Impala Linear Corporation
INF	Infineon
INTEL	Intel Corporation

Сокращение	Полное название фирмы
INTRO	Intronics, Inc.
IO	IOtech, Inc.
IPC	Interpoint Corporation
IR	International Rectifier Corp.
ISD	Information Storage Devices, Inc
ISOC	Isocom Incorporated
ISS	Integrated Silicon Solution Inc.
IST	International Semiconductor Technologies
ITI	Interface Technology, Inc.
ITT	ITT Semiconductor
ITTI	Integrated Telecom Technology, Inc.
IXYS	IXYS Corporation
JGD	Japan Gude Electronic Devices
KAWAS	Kawasaki LSI, USA
KEC	Korean Electr. Corp.
KEMET	KEMET
KRUE	Krueger Company
LAMB	Lambda Advanced Analog
LANSD	Lansdale Semiconductor, Inc.
LATT	Lattice Semiconductor Corp.
LD	Logic Devices Inc.
LECRO	LeCroy Corporation
LEVEL	Level One
LG	LG Semicon Company, Ltd.
LINF	Linfity Microelectronics
LINT	Lintel Security S.A.
LIS	Linear Integrated Systems
LM	Lockheed Martin
LRC	Leshan Radio Company, Ltd.
LSIC	LSI Computer Systems, Inc.
LSIL	LSI Logic Corporation
LT	Linear Technology Corporation
LUC	Lucent Technologies Inc.
M/A	M/A-COM, Inc.
MALL	Mallory
MARV	Marvell Semiconductor, Inc.
MATRA	Matra MHS, Inc.
MATS	Matsuo
MAX	Maxim Integrated Products
MC	Mini-Circuits
MCC	Micro Commercial Components
MCHIP	Microchip Technology, Inc.
MCS	Microsemi
MICR	Micrel
MICRO	Microtek International, Inc.
MII	Micropac Industries, Inc.
MISI	Micronix Integrated Systems, Inc.
MITEL	Mitel Semiconductor

Список фирм-производителей

Сокращение	Полное название фирмы
MTS	Mitsubishi Electronics America, Inc.
ML	Micro Linear
MLINK	MetaLink Corporation
MNC	Micro Networks Company
MOSAI	Mosaic Semiconductor, Inc.
MOSEL	MoseVitelic
MOSYS	MOSYS
MOT	Motorola Semiconductor Products
MPSC	MagePOWER Semiconductor Corporation
MR	MicroRel
MSIC	Mixed Signal Integration Corporation
MSIS	MSIS Semiconductor, Incorporated
MTI	Micron Technology, Inc.
MUR	Murata
MUSIC	Music Semiconductors, Inc.
MXC	MXCOM, Inc.
NACC	NACC
NANO	Nanoteq (Pty) Ltd
Nat	National Semiconductor
NCM	NCM Corporation
NEC	NEC Electronics Inc.
NEWP	Newport Components Limited
NEXC	Nexcom Technology, Inc.
NI	National Instruments
NJR	NJR Corporation
NOHAU	Nohau Corporation
NOVER	Nover
NPC	Nippon Precision Circuits Ltd.
NPX	NPX Corporation
NS	National Semiconductor Corporation
NTE	NTE Electronics, Inc.
OAK	Oak Technology, Inc.
OEI	Optical Electronics Inc.
OKI	OKI Semiconductor, Inc.
ON	ON Semiconductors
ONCH	OnChip Systems, Inc.
OPTEK	Optek Technology, Inc.
OPTI	OPTI Inc.
OPTO	Optotek Limited
ORBIT	Orbit Semiconductor Inc.
ORION	Orion Instruments, Inc.
OXFOR	Oxford Micro Device, Inc.
PAN	Panasonic Industrial Company/Electronic Comp.
PANJIT	Panjit Semiconductor
PARAD	Paradigm Technology, Inc.
PCA	PCA Electronics Inc.
PCC	Power Convertibles Corporation
PECG	Philips ECG

Сокращение	Полное название фирмы
PEPS	Performance Electronic Packaging Services
PERIC	Pericom Semiconductor Corporation
PHIL	Philips Semiconductors
PHYLO	Phylon Inc.
PI	Power Integrations, Inc.
PLESS	GEC Plessey Semiconductors
PLX	PLX Technology, Inc.
PMCS	PMCSierra
PMD	Performance Motion Devices, Inc.
PSC	Performance Semiconductor Corp.
PT	Power Trends
QLC	QuickLogic Corp
QLOG	QLogic Corporation
QS	Quality Semiconductor
QUALC	Qualcomm Incorporated
R&E	R&E International, Inc
RAMTR	Ramtron Corporation
RAYTH	Raytheon Company
REALT	Realtek Semiconductor Corporation
REN	Renesas
RFM	RF Micro Devices
RICOH	Ricoh Corporation
RMV	RMV Electronics Inc.
ROCH	Rochester Electronics Incorporated
ROCK	Rockwell Semiconductor Systems
ROHM	ROHM Corporation
S+M	Siemens Matsushita Components.
SAMS	Samsung Semiconductor, Inc.
SANYO	Sanyo Semiconductor Corporation
SCI	Silicon Composers, Inc.
SEEQ	SEEQ Technology, Incorporated
SEI	Space Electronics Incorporated
SEIKO	Seiko Instruments USA, Inc.
SEMT	Semtech Corporation
SENS	Sensory, Inc.
SEPON	Seponix Corporation
SGS	SGS-Thompson
SHARP	Sharp Electronics Corporation
SIEM	Siemens Microelectronics Inc.
SIGN	Signum Systems
SIL	Vishay Siliconix
SILIC	Silicom Inc.
SIMT	Simtek Corporation
SINC	Sincera
SIPEX	Sipex Corporation
SIS	SIS Microelectronics, Inc.
SMC	Standard Microsystems Corporation
SMOS	SMOS Systems, Inc.

Список фирм-производителей

Сокращение	Полное название фирмы
SMS	Samsung Microwave Semiconductor, Inc.
SOFT	Soft Device
SOLIT	Solitron Devices, Inc.
SONY	Sony Semiconductor Company of America
SOUTH	South African MicroElectronic Systems (Pty) Ltd
SPACE	Space Research Technology, Inc.
SPT	Signal Processing Technologies
SS	Silicon Systems Inc.
SST	Silicon Storage Technology, Inc.
STANF	Stanford Telecommunications Inc.
STM	ST Microelectronics, Inc.
SUMIT	Sumitomo Metal Industries, Ltd.
SUN	Sun Microsystems, Inc.
SUPER	Supertex, Inc.
SYFER	Syfer
SYMB	Symbios Logic
SYNER	Synergy Semiconductor Corporation
SYNT	Syntax Technology Inc.
SYSTR	Systonix, Inc.
TDK	TDK Semiconductor Corp.
TECH	Technitrol Pulse Components Div.
TELC	TelCom Semiconductor
TELEF	Vishay Telefunken
TELT	Teltone Corporation
TEMIC	Temic Semiconductors
Tfk	Telefunken (Vishay-Telefunken)
THAL	Thaler Corp
THAT	THAT Corporation
THES	Thesys Gesellschaft fur Mikroelektronik mbH
THIRD	Third Domain, Inc.
THOMS	Thomson Components and Tubes Corporation
TI	Texas Instruments, Inc.
TLSI	TLSI Incorporated
Tok	Toko Inc.
TOKO	Toko America Incorporated
TOSH	Toshiba America Electronic Components, Inc.
TRANS	TranSwitch Corporation
TRID	Trident Microsystems Incorporated
TRIQ	TriQuint Semiconductor
TRITE	TriTech Microelectronics

Сокращение	Полное название фирмы
TSC	Taiwan Semiconductor
TSENG	Tseng Labs, Inc.
TSQW	Tsquare, Inc.
TUNDR	Tundra Semiconductor Corporation
TURBO	Turbo IC, Inc.
UMC	United Microelectronics Corporation
UNITR	Unitrode Integrated Circuits Corp.
UNIV	Universal Semiconductor Inc.
US M	US MikroChips, Inc.
USAR	USAR Systems, Inc.
UTM	United Technologies Microelectronics Center
V3	V3 Semiconductor
VADEM	Vadem
VANT	Vantis Corporation
VETRA	Vetra Systems Corporation
VIA	VIA Technologies, Inc
VIS	Vishay Semiconductors (Gen Semi, Tfk, Sil etc)
VISH	Lite On (Vishay Lite On)
VITES	Vitesse Semiconductor Corp.
VITR	Vitramon
VLSI	VLSI Technology Inc.
VORT	Vortex Incorporated
VTC	VTC Inc.
WAFER	Waferscale Integration Inc.
WD	Western Digital Corporation
WDC	The Western Design Center, Inc.
WEIT	Weitron
WELTR	Weltrend
WHITE	White Microelectronics
WINB	Winbond Electronics Corp
WOLF	Wolfson Microelectronics
WTE	WTE Power Semiconductors
XECOM	Xecom, Inc.
XICOR	Xicor, Inc.
XILIN	Xilinx Corp.
YAGEO	Yageo
YAMA	Yamaha Corp of America
ZAXT	Zaxtek, Inc.
ZETEX	Zetex
ZOWIE	Zowie Technology Corporation

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

—	вывод отсутствует	p.c.	вывод не подключен
A	анод	out	выход
a	соединено с анодом	pd	несимметричный диностор для защиты оборудования связи
ACC	погрешность	P_D	рассеиваемая мощность
B	база	R_{25}	сопротивление температурного датчика
C	коллектор	$R_{DS(on)}$	сопротивление канала в открытом состоянии
C_{10B}	емкость при напряжении на варикале 10 В	R_{ON}	сопротивление ключа в открытом состоянии
C_{25B}	емкость при напряжении на варикале 25 В	R-R	вход/выход полного размаха (rail-to-rail)
C_{2V}	емкость при напряжении на варикале 2 В	R_Z	динамическое сопротивление
C_{2V}/C_{30V}	отношение емкостей для различных напряжений	S	исток
ca	с общим анодом	Si	кремний
cc	с общим катодом	substr	подложка
C_D	емкость диода	T_{AMB}	температура окружающей среды
C_{ESS}	входная емкость полевого транзистора	TC_{VOUT}	температурный коэффициент выходного напряжения
Com	общий	TC_{VZ}	температурный коэффициент напряжения стабилизации
comp	комплемментарный	t_{OFF}	время выключения
C_T	суммарная емкость	t_{PD}	задержка переключения
D	сток	t_{RES}	длительность сброса
DD	динамический диапазон	t_{RR}	время обратного восстановления
DT	рабочий цикл	t_{STUP}	задержка включения
E	эмиттер	T_{TH}	температурный порог срабатывания
f_{BD}	ширина полосы пропускания	T_{THAC}	точность температурного порога срабатывания
f_{CLK}	тактовая частота	T_{THL}	нижний температурный порог срабатывания
f_{DR}	скорость передачи данных	T_{THU}	верхний температурный порог срабатывания
f_{IN}	входная частота	V_{BR}	напряжение пробоя
f_{OSC}	частота генератора	V_{BRDSS}	напряжение пробоя сток-исток
f_P	рабочая частота	V_C	напряжение фиксации (коллектора)
f_T	граничная частота	V_{CB}	пороговое напряжение circuit-breaker thresholds
f_{UG}	частота единичного усиления	V_{CB0}	постоянное напряжение коллектор — база
G	затвор/управляющий электрод	V_{CC}	положительное напряжение питания
Gain	коэффициент усиления	$V_{CE(sat)}$	напряжение насыщения коллектор — эмиттер
g_m	прямая проводимость полевого транзистора	V_{CE0}	постоянное напряжение коллектор эмиттер
G_{MA}	коэффициент усиления мощности	V_{DS}	напряжение сток — исток
gnd	земля	V_F	прямое напряжение
h_{21}	статический коэффициент передачи тока	V_{GS}	напряжение затвор — исток
i.c.	вывод внутренне подключен (не подсоединять к внешней точке)	V_{SS}	напряжение пробоя затвор исток
IC	ток коллектора	V_{GSTH}	пороговое напряжение на затворе
I_{CAT}	ток катода	V_{OD}	дифференциальное выходное напряжение
I_{CS0}	обратный ток перехода коллектор — база	V_{OH}	выходное напряжение высокого уровня
I_{CH}	ток заряда батареи	V_{OL}	выходное напряжение низкого уровня
I_D	ток стока	V_{OSI}	напряжение смещения
I_{DSS}	ток стока при нулевом потенциале на затворе	V_{OUT}	выходное напряжение
I_F	прямой ток	V_R	обратное напряжение
I_G	ток затвора	V_{REF}	опорное напряжение
I_{leak}	ток утечки	V_{TR}	пороговое напряжение срабатывания
in	вход	V_{TROV}	порог превышения допустимого напряжения
I_{PP}	пиковый импульсный ток разряда	V_{VM}	напряжение выключения
I_R	обратный ток	V_Z	напряжение стабилизации
I_T	средний ток в состоянии включения	x	безразличное состояние
I_Z	ток стабилизации	Z_Z	дифференциальное сопротивление
I_{ZM}	максимальный ток стабилизации	Z_{ZT}	дифференциальное сопротивление в контрольной точке
I_{ZT}	ток стабилизации в контрольной точке		
K	катод		
k	соединено с катодом		
LT	суммарная индуктивность		
max	максимальное значение		
min	минимальное значение		

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ ПРИБОРА

- 2-AND — 2-входный вентиль И
 2-NAND — 2-входный вентиль И-НЕ
 2-NOR — 2-входный вентиль ИЛИ-НЕ
 3-stbuff — неинвертирующий буфер с тремя состояниями
 abc — контроллер тока смещения
 ADC — аналого-цифровой преобразователь
 amp — усилитель
 amux — аналоговый мультиплексор
 asw — аналоговый ключ
 ats — аналоговый температурный датчик
 atten — аттенуатор
 batprot — схема защиты литиевых аккумуляторов
 bcontr — контроллер для повышающих dc-dc-преобразователей
 btd — динистор
 buf — буфер
 byd — быстрый выпрямительный диод с «мягким» восстановлением
 byg — быстрый высоковольтный выпрямительный диод с «мягким» восстановлением
 byh — выпрямительный диод общего применения
 byv — высоковольтный выпрямительный диод
 cid — стабилизатор тока
 chg — контроллер зарядного устройства для аккумуляторов
 cmp — компаратор
 cpin — переключаемый pin-диод
 cpreg — стабилизатор напряжения с накачкой заряда
 CSA — токовый усилитель
 d — диод (сборка)
 DA — дифференциальный усилитель
 DAC — цифро-аналоговый преобразователь
 dcdc — DC/DC-преобразователь
 di — импульсный диод
 dih — импульсный диод с большим рабочим током
 di — диод общего применения с малым током утечки
 dnMESFET — *n*-канальный полевой транзистор с барьером Шоттки на основе GaAs с двумя затворами
 dnmixer — преобразователь-смеситель с понижением частоты сигнала
 DnMOS — «цифровой» *n*-канальный МОП-транзистор
 dnMOS — *n*-канальный МОП-транзистор с двумя затворами
 Dnpn — «цифровой» *n-p-p*-транзистор
 dnpn — составной *n-p-p*-транзистор
 dOA — двухканальный операционный усилитель
 DpMOS — «цифровой» *p*-канальный МОП-транзистор
 Dppn — «цифровой» *pnp*-транзистор
 dpnp — составной *pnp*-транзистор
 Dpot — цифровой потенциометр
 dr — выпрямительный диод
 drv — драйвер МОП-транзистора
 dsw — цифровой ключ
 dts — цифровой температурный датчик
 dtv — диод для переключения диапазонов телевизионного приемника
 dz — стабилитрон
 fd — быстродействующий диод
 fid — быстродействующий импульсный диод
 fescap — программируемый конденсатор
 frd — быстро восстанавливающийся выпрямительный диод
 gen — программируемый генератор сигналов
 hscntr — контроллер «горячей замены»
 IA — инструментальный усилитель
 JFETOA — операционный усилитель с полевыми транзисторами на входе
 LA — логарифмический усилитель
 levtrans — преобразователь уровней логических сигналов
 ltemp — компаратор локальной температуры
 LVDSdrv — LVDS-драйвер линии
 mmic — СВЧ-микросхема
 mrc — схема сброса для микропроцессора
 nFET — *n*-канальный полевой транзистор с управляющим *p-p*-переходом
 nMESFET — *n*-канальный полевой транзистор с барьером Шоттки на основе GaAs
 nMOS — *n*-канальный МОП-транзистор
 npn — *p-p-p*-транзистор
 O — однопереходный транзистор
 OA — операционный усилитель
 PD — детектор ВЧ-сигнала
 pd — несимметричный динистор для защиты оборудования связи
 pFET — *p*-канальный полевой транзистор с управляющим *p-p-p*-переходом
 pin — *p-i-p*-диод
 pMOS — *p*-канальный МОП-транзистор
 pnp — *p-p-p*-транзистор
 ppnp — программируемый однопереходный транзистор
 prot — микросхема защиты аналоговых входов
 PWM — ШИМ-контроллер для изолированных источников питания
 pz — защитный стабилитрон
 rec — приемник
 reg+mc — стабилизатор напряжения со схемой сброса для микропроцессора
 reg — стабилизатор напряжения
 reg- — стабилизатор отрицательного напряжения
 reg+ — стабилизатор положительного напряжения
 rts — резистивный температурный датчик
 Schmir — инвертор с триггером Шмитта на входе
 SchmNAND — 2-входный вентиль И-НЕ с триггером Шмитта на входе
 scvcon — преобразователь напряжения на переключающих конденсаторах
 sd — импульсный переключающий диод
 shd — диод Шоттки
 shy — выпрямительный диод Шоттки
 spd — симметричный динистор для защиты оборудования связи
 SPM — ШИМ-контроллер для понижающих dc-dc-преобразователей
 spz — симметричный защитный стабилитрон
 sw — переключатель (ключ)
 swd — подавитель дребезга контактов
 tempsw — пороговый датчик температуры
 trans — приемопередатчик
 trnsmit — передатчик
 TSPD — тиристорный прибор защиты
 upmxr — преобразователь-смеситель с повышением частоты сигнала
 var — варикап
 VCO — генератор управляемый напряжением
 vcon — преобразователь напряжения
 vcscon — инвертирующий преобразователь напряжения с накачкой заряда
 vd — монитор напряжения (детектор напряжения)
 VFC — преобразователь напряжение-частота
 vibrv — драйвер вибровонка
 vref — источник опорного напряжения
 vs — подавитель выбросов напряжения (супрессор)
 vseq — монитор напряжения для приборов с двумя напряжениями питания
 wdt — сторожевой таймер

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ КОРПУСОВ

JEDEC	EIAJ	PHILIPS SIEMENS CENTS MAXIM	ROHM	SANYO	HITACHI	MOTOROLA	TOSHIBA KEC
TO-236	SC-59	SOT-346	SMD/T3		MPAK2	SC-59	S-MINI
TO-236AB	SC-59A	SOT/SOD-23	SSD/T3	CP	MPAK	SOT-23	
TO-243AA	SC-62	SOT-89A	MPT3	PCP	UPAK		PW-MINI
TO-243AB		SOT-89B					
TO-252-3	SC-63		CPT3				
TO-253		SOT-143	SMD/T4			SOT-143	
TO-253		SOT-143R					
		SOD-123				SOD-123	
	SC-76	SOD-323	UMD2				USE
	SC-82A	SOT-343					
		SOT-343R			CMPAK-4		
		SOT-87					
	SC-70	SOT-323	UMD/T3	MCP	CMPAK	SOT-323	USM
	SC-74	SOT457	SMD/T6				SM6
	SC-74A	SOT23-5	SMD/T5				SMV
	SC-75A, SC90	SOT-416	EMD/T3	SMCP	SMPAK		SSM
	SC-79	SOD-523	EMD2				ESC
	SC-82		UMD/T4				USQ
	SC-88	SOT-363	UMD/T6				US6
	SC-88A	SOT-353	UMD/T5				USV
	SC61				MPAK-4		SMQ
	SC89	SOT490					ESM
			VMT3				USQ